PSMC

力晶積成電子製造股份有限公司

股票代號：6770

Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation

(原名：鉅晶電子股份有限公司)

公開說明書

(現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市用)

一、公司名稱：力晶積成電子製造股份有限公司

二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市用

(一)發行新股來源：現金增資發行新股。

(二)新股種類：記名式普通股，**每股面額新台幣壹拾元整**。

(三)股數：現金增資發行新股 130,000,000 股。

(四)金額：新台幣 1,300,000,000 元整。

(五)發行條件：

1.本次現金增資發行普通股 130,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣 1,300,000,000 元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣 43 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格新台幣 63.52 元為之，並以最低承銷價格之 1.16 倍為上限，故每股發行價格以新台幣 49.88 元溢價發行。

2.依公司法第 267 條規定，保留發行新股 15%，計 19,500,000 股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之，其餘 85%計 110,500,000 股全數委託證券承銷商對外辦理公開承銷。

3.本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

(六)公開承銷比例：本次現金增資發行新股總數 85%，共計 110,500,000 股。

(七)承銷及配售方式：同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第75頁。

四、本次發行之相關費用：

(一)承銷費用：包括輔導費用及承銷手續費用，合計新臺幣500萬元整。

(二)上市審查費用：新臺幣50萬元整。

(三)其他費用：包含會計師、律師及印刷等其他費用，合計約新臺幣280萬元整。

五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項，請參閱本公開說明書第2頁至5頁。

八、本公開說明書，適用於初次申請有價證券上市，並計畫以現金增資發行新股委託證券承銷商辦理上市前之公開銷售。

九、本公司係依上市審查準則第五條之規定申請股票上市之公司，屬科技事業，所營業務具有相當之風險性，請投資人特別注意。

十、初次上市承銷案件，掛牌後首五個交易日應無漲跌幅限制，投資人應注意交易之風險。

十一、本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依規定進行安定操作。

十二、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw/)

力晶積成電子製造股份有限公司 編製

中華民國一一〇年十一月二十二日刊印

本公司申請已公開發行普通股 3,405,196,242 股上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」審查後同意列為上市股票，並經臺灣證券交易所於 110 年 10 月 5 日以臺證上一字第 1101805401 號函報請金融監督管理委員會證券期貨局備查。

一、本次發行前實收資本之來源及比率

實收資本來源	金額(新臺幣元)	占實收資本額比率
設立資本	5,000,000,000	14.68%
減資退還股款	(2,056,415,055)	(6.04)%
減資彌補虧損	(443,584,945)	(1.30)%
盈餘轉增資	1,943,783,490	5.71%
發行新股收購力晶科技(股)公司相關營業及淨資產	22,608,182,200	66.39%
現金增資	7,000,000,000	20.56%
註銷股東拋棄持股	(3,270)	0.00%
合計	34,051,962,420	100.00%

二、公開說明書之分送計畫

(一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置本公司以供查閱。

(二)分送方式：依金融監督管理委員會證券期貨局規定方式辦理。

(三)索取方式：請透過網路至公開資訊觀測站(http：//mops.twse.com.tw)查詢及下載。

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司　網址：https://www.yuanta.com.tw
地址：臺北市中山區南京東路三段225號13、14F　電話：(02)27181234
名稱：群益金鼎證券股份有限公司　網址：https://www.capital.com.tw
地址：臺北市民生東路三段156號14樓之3　電話：(02)87898888
名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司　網址：https://www.entrust.com.tw
地址：臺北市民生東路四段54號5樓　電話：(02)25456888
名稱：兆豐證券股份有限公司　網址：https://www.megasec.com.tw
地址：臺北市忠孝東路二段95號3樓　電話：(02)23278988
名稱：第一金證券股份有限公司　網址：https://www.firstsec.com.tw
地址：臺北市長安東路一段22號4樓　電話：(02)25636262
名稱：合作金庫證券股份有限公司　網址：https://www.tcfhc-sec.com.tw
地址：臺北市松山區長安東路二段225號C棟6樓　電話：(02)21738888
名稱：彰化商業銀行股份有限公司　網址：https://www.bankcnb.com
地址：臺北市中山區中山北路二段57號　電話：(02)25362951
名稱：台灣土地銀行股份有限公司　網址：https://stock.landbank.com.tw
地址：臺北市中正區延平南路81號　電話：(02)23483919
名稱：台新綜合證券股份有限公司　網址：https://www.tssco.com.tw
地址：臺北市中山北路二段44號2樓　電話：(02)23268898
名稱：元富證券股份有限公司　網址：https://www.masterlink.com.tw
地址：臺北市敦化南路二段97號22樓　電話：(02)23255818

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　網址：http：//www.capital.com.tw
地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓　電話：(02)27023999

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：黃裕峰會計師、鍾鳴遠會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所　網址：http：//www.deloitte.com.tw
地址：台北市信義區松仁路100號20樓　電話：(02)27259988

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

律師姓名：陳維鈞律師　　網址：-

事務所名稱：傑宇法律事務所　　電話：(02)27150106

地址：台北市松山區復興北路 167 號 6 樓

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發　言　人：譚仲民　　代理　發言人：邵章榮

職　　稱：副總經理　　職　　稱：副總經理兼財務長

聯 絡 電 話 ：(02)25170055　　聯 絡 電 話 ：(03)5795000

電子郵件信箱：erictang@powerchip.com　　電子郵件信箱：jerrys@powerchip.com

十三、本公司網址：http://www.powerchip.com

力晶積成電子製造股份有限公司

產業營運及其他重要風險

一、產業風險(請參閱第 54 頁)

(一) 同業競爭壓力增加

近年半導體產業主要支撐力道來自於行動裝置、5G、AI 等產品，各相關晶圓代工廠亦受惠，引起業界關注。而近年中國政府致力於半導體產業扶植，以打造產業鏈一條龍為目標，積極投入設備及廣納人才。在全球代工產能供給增加的情況下，可能會面臨與同業競爭壓力。

因應對策

本公司專注於晶圓代工業務，以世界級同步的技術，搭配國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的代工服務，以共創事業高峰。至今已陸續引進不同的代工客戶，客戶的產品可應用的範圍涵蓋了 3C 應用領域－電腦、無線通訊、消費性電子及車用電子等。

同時藉由擴大與全球產官學研究機構共同進行相關製程技術開發，以期提早掌握前瞻技術，有效縮短研發時程，降低專利與技術移轉成本。本公司持續提供更優質的服務、產品及多元代工模式，以持續深化與客戶良好關係。透過 12 吋廠與 8 吋廠整合，提供客戶更完整的產品線及更完善的服務品質。

二、營運風險(請參閱第 55 頁)

(一)產能擴充之可能風險

因 12 吋代工客戶產能需求持續攀升，本公司近期之 12 吋產能無法滿足客戶需求。為滿足中長期營運規劃，本公司在充分評估後，已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構 12 吋生產基地。惟因需求預測會隨著市場環境變化而產生顯著的改變，當需求減少時，已添購的機器設備及增聘的人員等將造成對本公司財務表現產生負面的影響。

因應對策

本公司會持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，若市場需求不如預期時，會及時地調整產能計劃，以降低對於公司財務表現的負面影響，且相關投資計畫尚在規劃中，原則以分期、分階段，以公司財務可負擔，最小風險下擴充廠房及產能，同時兼顧公司穩健成長與滿足客戶產能需求。

本公司亦將擴廠設備風險轉嫁給客戶共同承擔，對上游 IC 設計業者來說，即使本身公司設計具有競爭力，但沒有配合製造的產能也無濟於事，因此未來五年，晶圓代工產能將成為兵家必爭之地，而客戶端爭搶產能動作更加積極。目前本公司與部分客戶間採取 Consign 的模式，由客戶購買機器設備租予本公司，再由本公司代工產出產品，客戶可確保後續晶圓取得無虞，本公司也能降低購買大量設備後需求減緩的風險。

(二)有關智慧財產權之風險

本公司及子公司係以自行研發的製程技術、營業秘密、相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，然而尚無法保證營業秘密及相關 know-how 不被竊取或仿效，若發生此情事，將導致本公司營收減少之可能性，也有可能在不知情的情況下侵害到他公司的智慧財產權，若有相關之訴訟可能導致本公司有無法製造特定產品的風險。

因應對策

本公司及子公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益損失的可能性。包含積極主張及保護本公司所屬之智慧財產權，對於研發成功之產品基於智慧財產權，皆有申請專利保護。本公司設有智權室，以防止製程中有侵害他人智慧財產權之情事，另外對於使用到的專利，皆有取得其他公司的授權，避免有侵權的風險。

三、其他重要風險(請參閱第 2~5 頁)

本公司其他重要風險請詳本公開說明書「壹、二、風險事項」之說明。

力晶積成電子製造股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新臺幣 34,051,962 仟元	公司地址：新竹市科學工業園區力行一路 18 號	電話：(03)5795000
設立日期：97 年 04 月 17 日	網址：http://www.powerchip.com	
上市日期：不適用	上櫃日期：不適用	公開發行日期：109 年 10 月 12 日 / 管理股票日期：不適用

負責人	董事長：黃崇仁 總經理：謝再居	發　言　人： 代理發言人：	姓名：譚仲民　職稱：副總經理 姓名：邵章榮　職稱：副總經理兼財務長

股票過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　網址：www.capital.com.tw
地　　址：台北市敦化南路二段 97 號地下 2 樓　電話：(02)27023999

股票承銷機構：

名稱：元大證券股份有限公司	網址：http://www.yuanta.com
地址：台北市中山區南京東路三段 225 號 13、14 樓	電話：(02)27181234
名稱：群益金鼎證券股份有限公司	網址：https://www.capital.com.tw
地址：臺北市民生東路三段 156 號 14 樓之 3	電話：(02)87898888
名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司	網址：https://www.entrust.com.tw
地址：臺北市民生東路四段 54 號 5 樓	電話：(02)25456888
名稱：兆豐證券股份有限公司	網址：https://www.megasec.com.tw
地址：臺北市忠孝東路二段 95 號 3 樓	電話：(02)23278988
名稱：第一金證券股份有限公司	網址：https://www.firstsec.com.tw
地址：臺北市長安東路一段 22 號 4 樓	電話：(02)25636262
名稱：合作金庫證券股份有限公司	網址：https://www.tcfhc-sec.com.tw
地址：臺北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 6 樓	電話：(02)21738888
名稱：彰化商業銀行股份有限公司	網址：https://www.bankcnb.com
地址：臺北市中山區中山北路二段57號	電話：(02)25362951
名稱：台灣土地銀行股份有限公司	網址：https://stock.landbank.com.tw
地址：臺北市中正區延平南路81號	電話：(02)23483919
名稱：台新綜合證券股份有限公司	網址：https://www.tssco.com.tw
地址：臺北市中山北路二段44號2樓	電話：(02)23268898
名稱：元富證券股份有限公司	網址：https://www.masterlink.com.tw
地址：臺北市敦化南路二段97號22樓	電話：(02)23255818

最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所　網址：http://www.deloitte.com.tw
黃裕峰會計師、鍾鳴遠會計師　電話：(02)27259988
地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

複核律師：傑宇法律事務所 陳維鈞律師　網址：-
地址：台北市松山區復興北路 167 號 6 樓　電話：(02)2715-0106

信用評等機構：不適用　電話：不適用　地址：不適用　網址：不適用

評等標的	發行公司：不適用	無□；有□，評等日期：不適用　評等等級：不適用
	本次發行公司債：不適用	無□；有□，評等日期：不適用　評等等級：不適用

董事選任日期：109 年 05 月 27 日，任期：3 年	監察人選任日期：不適用(本公司設立審計委員會)
全體董事持股比例：28.47% (110 年 09 月 30 日)	全體監察人持股比例：不適用(本公司設立審計委員會)

董事、監察人及持股 5%以上股東及其持股比例：28.47% (110 年 09 月 30 日)

職　稱	姓　名	持股比例	職　稱	姓　名	持股比例
董 事 長	黃崇仁	3.40%	獨立董事	吳重雨	0%
董　事	謝再居	0.05%	獨立董事	張嘉臨	0%
董事暨 5%以上股東	力晶科技股份有限公司 代表人：徐清祥	24.54%	獨立董事	林憲銘	0%
董　事	仁典投資股份有限公 代表人：邵章榮	0.48%	獨立董事	林本堅	0%
			獨立董事	葉疏	0%

主要股東之職稱、姓名及持股比例：請參閱本公開說明書第 33 頁　技術股股東之職稱、姓名及持股比例：無

各級單位主管與技術、研究發展主管暨相關技術、研究發展人員之職稱、姓名及持股比例：
請參閱本公開說明書第 9-12 頁

工廠地址：		電話：
P1/2 廠	新竹市科學園區力行一路 12 號	(03)5795000
P3 廠	新竹市科學園區力行路 16-1 號	(03)5791000
8A 廠	新竹市科學園區力行一路 18 號	(03)5656000
8AD 廠	新竹市科學園區篤行一路 10 號 4F	(03)5656000
8B 廠	苗栗縣竹南科學園區科北二路 6 號	(03)7539200

主要產品： 邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品	市場結構(109 年度)：內銷 72.10% 外銷 27.90%	參閱本文之頁次 第 53 頁
風　險　事　項	請參閱本公開說明書公司概況風險事項之記載	參閱本文之頁次 第 2 頁~第 5 頁

去(109)年度	營業收入：45,684,615 仟元 稅前淨利：4,799,073 仟元　每股盈餘：1.23 元	參閱本文第 82 頁
本次募集發行有價證券種類及金額	請詳本公開說明書封面	
發行條件	請詳本公開說明書封面	
募集資金用途及預計產生效益概述	請參閱本公開說明書第 75 頁	
推薦證券商執行過額配售及價格穩定之相關資訊	本公司已與主辦證券承銷商簽訂過額配售協議書約定相關事宜。	
本次公開說明書編印日期：110 年 11 月 22 日	刊印目的：現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市用	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄		

目錄

壹、 公司概況 1
一、公司簡介 1
(一)設立日期 1
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話 1
(三)公司沿革 1
二、風險事項 2
(一)風險因素 2
(二)訴訟或非訟事件 4
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響 5
(四)發行公司於最近一個會計年度或申請上市會計年度內，其子公司符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項重要子公司標準之一者，應增列該子公司之風險事項說明 5
(五)外國發行公司應增列敘明外國發行公司註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施 5
(六)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明擁有之關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式，及因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施 5
(七)其他重要事項 5
三、公司組織 6
(一)組織系統 6
(二)關係企業圖 8
(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管與技術及研究發展人員資料 9
(四)董事及監察人 13
(五)發起人資料 19
(六)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 20
(七)發行公司之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經（學）歷、持有股份、目前兼任發行公司及其他公司之職務、與發行公司董事之關係及對發行公司實質控制情形，另外國發行公司尚應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任 30
四、資本及股份 31
(一)股份種類 31
(二)股本形成經過 31
(三)最近股權分散情形 32
(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 39
(五)公司股利政策及執行狀況 39
(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 39
(七)員工、董事及監察人酬勞 39
(八)公司買回本公司股份情形 40
五、公司債(含海外公司債)辦理情形 40

六、特別股辦理情形 40
七、參與發行海外存託憑證之辦理情形 40
八、員工認股權憑證辦理情形 41
九、限制員工權利新股辦理情形 45
十、併購辦理情形 45
十一、受讓他公司股份發行新股辦理情形 45
貳、 營運概況 46
一、公司之經營 46
(一)業務內容 46
(二)市場及產銷概況 53
(三)最近二年度及截至公開說明書刊印日止 60
(四)環保支出資訊 60
(五)勞資關係 62
(六)有無因應景氣變動之能力 63
(七)發行公司及其子公司(包括母子公司間交易事項)之關係人間交易事項是否合理 63
二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產 63
(一)自有資產 63
(二)使用權資產 64
(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率 64
三、轉投資事業 65
(一)轉投資事業概況 65
(二)綜合持股比例 65
(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響 65
(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數 65
四、重要契約 66
五、以科技事業申請股票上市者，應增列事項 66
參、 發行計畫及執行情形 71
一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載事項 71
二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項 75
三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項 78
四、本次併購發行新股應記載事項 78
肆、 財務概況 79
一、最近五年度簡明財務資料 79
(一)簡明資產負債表及綜合損益表股東會 79
(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響 83

(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見 83
(四)本國發行公司自公開發行後最近連續七年，或外國發行公司最近連續七年財務報告皆由相同會計師查核簽證者，應說明未更換會計師之原因、目前簽證會計師之獨立性暨公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施 83
(五)財務分析—國際財務報導準則 84
(六)會計科目重大變動說明 87
二、財務報表應記載事項 89
(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告 89
(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告，但不包括重要會計項目明細表 89
(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露 89
三、財務概況其他重要事項 89
(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響 89
(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露資訊 89
(三)期後事項 89
(四)其他 89
四、財務狀況及經營結果之檢討分析 89
(一)財務狀況 89
(二)財務績效 90
(三)現金流量 91
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響 92
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 92
(六)其他重要事項 92
伍、 特別記載事項 93
一、內部控制制度執行狀況 93
(一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議 93
(二)最近三年度內部稽核發現之重大缺失及其改善情形 93
(三)內部控制聲明書 93
(四)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形 93
二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告 93
三、證券商承銷商評估總結意見 93
四、律師法律意見書 93
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見 93
六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時，經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形 93
七、本次募集與發行有價證券於申報生效時，經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項 93
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開

說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形 93
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容 93
十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形 93
十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書 93
十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，推薦證券商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書 93
十三、發行公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，應出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具承諾日後有往來時必無非常規交易 ... 93
十四、發行公司於申請上市會計年度及其上一會計年度已辦理與辦理中之大量現金增資發行新股，及是否產生相當效益之評估 93
十五、發行公司是否有與其他公司共同使用申請貸款額度 94
十六、發行公司有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人 94
十七、具有上市審查準則第六條之一所規定申請之公司者，應增列事項 94
十八、具有上市審查準則第十六條所規定之公司者，應增加揭露資訊 94
十九、發行公司有上市審查準則補充規定第十條或第二十六條所列各款情事者，應將該非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會 94
二十、本國發行公司為普通申請公司債上市者，應增列事項 94
二十一、充分揭露發行公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式 94
二十二、發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於申請公司股票上市後對財務報表可能之影響 94
二十三、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人就目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見 94
二十四、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明 94
二十五、其他必要補充說明事項 94
二十六、依上市審查準則第四條第二項、第三項、或第二十八條之一第五項、第六項、或屬科技事業、文化創意事業申請股票初次上市，且委託證券承銷商辦理上市前公開銷售、並保留一定比例採洽商銷售方式辦理配售者，應增列配售名單、協議認購股數、協議配售總股數、占公開銷售總股數之比例及配售股票之集保期間與賣出限制等事項 119
二十七、證券承銷商應就前款配售名單合理性、配售股數、占公開銷售總股數之比例、配售股票賣出限制、繳款資力及協議事項妥適性出具評估意見 119
二十八、本國發行公司或外國發行公司前款規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售者，本國發行公司或外國發行人及證券承銷商應出具絕無以任何方式或名目，提供

直接或間接利益予洽商銷售投資人或其指定人之聲明書。該洽商銷售投資人亦應出具絕無要求或收取發行公司或承銷商以任何方式或名目提供之直接或間接利益之聲明書 119
二十九、外國發行公司有上市審查準則第二十八條之七第一項第三款或三十四條第二項第二款情事者，應將有關股東權益保護之重要事項因與註冊地國法令之強制規定牴觸，致未能增訂於公司章程或組織文件之重大差異充分揭露 119
三十、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項 120
(一)董事會運作情形 120
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 124
(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 126
(四)薪酬委員會運作情形 130
(五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 132
(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 140
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 142
(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總 142
(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露 142
三十一、發行公司辦理公司治理資訊揭露之情形 143
陸、 重要決議、公司章程及相關法規 147
一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表) .. 147
二、未來股利發放政策 147
三、未來辦理增資計畫及其對獲利能力稀釋作用之影響 147

附件：

附件一、一〇八年度合併財務報告及會計師查核報告
附件二、一〇九年度合併財務報告及會計師查核報告
附件三、一一〇年第三季合併財務報告及會計師核閱報告
附件四、一〇八年度個體財務報告及會計師查核報告
附件五、一〇九年度個體財務報告及會計師查核報告
附件六、內部控制聲明書
附件七、內部控制制度審查報告
附件八、證券承銷商評估總結意見
附件九、律師法律意見書
附件十、不得退還或收取承銷相關費用之聲明書
附件十一、無非常規交易情事之聲明書
附件十二、不受理特定對象投標聲明書
附件十三、誠信聲明書
附件十四、與本次發行有關之決議文(含盈餘分配表)
附件十五、公司章程及新舊條文對照表
附件十六、初次申請上市承諾事項
附件十七、承銷價格計算書

附件十八、股票初次上市證券承銷商評估報告
附件十九、股票上市前現金增資發行新股之證券承銷商評估報告

壹、公司概況

一、公司簡介

(一)設立日期：民國97年04月17日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

名稱		地址	電話
總公司		新竹市科學園區力行一路 18 號	(03)5795000
工廠	P1/2 廠	新竹市科學園區力行一路 12 號	(03)5795000
	P3 廠	新竹市科學園區力行路 16-1 號	(03)5791000
	8A 廠	新竹市科學園區力行一路 18 號	(03)5656000
	8AD 廠	新竹市科學園區篤行一路 10 號 4F	(03)5656000
	8B 廠	苗栗縣竹南科學園區科北二路 6 號	(03)7539200
分公司		無	

(三)公司沿革

年度	重要記事
97 年	◆鉅晶電子股份有限公司成立。 ◆實收資本額新臺幣 5,000,000 仟元。
98 年	◆0.18 微米 LCD 顯示驅動晶片量產。
99 年	◆0.18 微米 微處理控制晶片量產。
100 年	◆0.18 微米 電源管理晶片量產。
101 年	◆0.18 微米 Power MOSFET 量產。
102 年	◆接獲日本 IDM 大廠 500V HV MOSFET 訂單。
103 年	◆42V e-label IC 量產。 ◆減資退還股款新臺幣 1,556,415 仟元及減資彌補虧損新臺幣 443,585 仟元，減資後實收資本額新臺幣 3,000,000 仟元。
104 年	◆接獲美國 IDM 大廠 LV MOSFET 訂單。 ◆8AD 篤行廠區量產。 ◆減資退還股款新臺幣 500,000 仟元，減資後實收資本額新臺幣 2,500,000 仟元。
105 年	◆接獲美國 IDM 大廠 0.35 微米 Power IC 訂單。
106 年	◆購入竹南科學園區聯合再生能源廠房，並命名為 8B 廠。 ◆700V 電源管理晶片量產。 ◆盈餘轉增資新臺幣 563,643 仟元，實收資本額新臺幣 3,063,643 仟元。
107 年	◆本公司更名為力晶積成電子製造股份有限公司(簡稱力積電)。 ◆盈餘轉增資新臺幣 523,032 仟元，實收資本額新臺幣 3,586,675 仟元。
108 年	◆8B 廠量產。 ◆盈餘轉增資新臺幣 857,109 仟元，實收資本額新臺幣 4,443,783 仟元。 ◆發行新股收購母公司力晶科技(股)公司之相關營業及淨資產，增資收購發行新臺幣 22,608,182 仟元，增資後實收資本額新臺幣 27,051,965 仟元。 ◆辦理現金增資普通股新臺幣 4,000,000 仟元，增資後實收資本額新臺幣 31,051,965 仟元。
109 年	◆經財團法人中華民國櫃檯買賣中心核准補辦公開發行，股票代號：6770。 ◆經財團法人中華民國櫃檯買賣中心核准登錄興櫃買賣，股票代號：6770。
110 年	◆辦理現金增資普通股新臺幣 3,000,000 仟元，增資後實收資本額新臺幣 34,051,965 仟元。

二、風險事項

(一)風險因素

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	108 年度	109 年度	110 年第三季
合併利息費用	523,363	678,183	526,895
合併營業收入淨額	35,897,121	45,684,615	45,865,144
合併利息費用占營業收人淨額比重	1.46	1.48	1.15

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

本公司 108~109 年度及 110 年第三季利息費用占當期營業收入淨額比重分別為 1.46%、1.48%及 1.15%，其中 109 年度占比增加，主係因動撥聯貸及短期借款，致利息費用增加，惟各期之合併利息費用占營業收人淨額占比微小，主要係本公司為營運需求及資本支出向金融機構借款所產生之融資利息，市場利率雖有所波動，尚不致對本公司營收及獲利造成重大不利之影響。本公司隨時觀察及分析金融市場利率變動對本公司所有付息負債所產生現金流量之影響，並與銀行保持良好關係，且適時評估所有付息負債可能遭遇之利率風險，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

(2)匯率變動

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	108 年度	109 年度	110 年第三季
合併淨外幣兌換損益	(68,070)	(316,469)	(191,342)
合併營業收入淨額	35,897,121	45,684,615	45,865,144
合併淨外幣兌換損益占營業收入淨額比重	(0.19)	(0.69)	(0.42)

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

本公司 108~109 年度及 110 年第三季淨外幣兌換損益占當期營業收入淨額比重分別為 (0.19)%、(0.69)%及(0.42)%，由於本公司資本支出及製造成本多以非新臺幣貨幣如美元及日圓支付，且收入亦以美元為主，匯率波動過大對本公司可能會有不利影響；本公司持續視匯率市場變動、實際部位和資金狀況，採自然避險及配合遠期外匯合約以規避匯率風險。

(3)通貨膨脹

本公司並無因受通貨膨脹而有產生重大影響，且本公司隨時注意市場價格波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係，以避免通貨膨脹對公司損益之不利影響。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

(1)本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等辦法，以適用於本公司之遵循依據。截至公開說明書刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證交易之情事。

(2)本公司從事衍生性金融商品交易以美金兌新臺幣及日幣之遠期匯率避險操作為主，係為規避外幣資產及負債因匯率波動所產生之風險，相關交易均以避險為目的，並嚴格遵循「取得或處分資產處理程序」作為執行衍生性金融商品交易之依據，故對公司無重大風險。

3.未來研究計畫及預計投入之研發費用

單位：新臺幣佰萬元

項目	研發計劃	預計完成量產時間	預計投入之研發費用
1	90nm CMOS Image Sensor 開發平台	110年度	1,943
2	110nm CMOS Image Sensor(BSI) 開發平台		
3	130nm 電源管理平台		
4	80nm/90nm 電源管理平台		
5	150nm 電源管理平台		
6	21nm DRAM 8GbDDR4 開發平台		
7	28nm S2G 開發平台		
8	24nm NAND Flash 開發平台		
9	40nm NOR Flash 開發平台		
10	110nm LCD(L)、 E-paper 專案		
11	150nm~180nm IMC M1OTP 專案		
12	110nm IMC EEPROM 專案		
13	110nm Power IC LDMOS 12V/30V 專案		
14	150nm Microbolometer 開發平台		
15	Discrete(IGBT/SJ/UMOS/DG)專案		
16	Discrete GaN 開發平台		

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，並諮詢相關專業人士，以充份掌握並因應市場環境變化，適時調整本公司相關營運策略。截至公開說明書刊印日止，本公司並無受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司所處半導體產業，產品、技術世代交替迅速，相關廠商不斷引進先進製程技術，擴增產能結果，往往造成供、需失衡，價格波動異常，因而導致公司營運起伏劇烈。

有鑑於此，本公司除持續關注市場變化及相關科技發展趨勢外，掌握市場契機，並致力於開發新產品、新客源以提昇公司長期之競爭能力。截至公開說明書刊印日止，尚無發生科技改變及產業變化而有影響財務業務之情事。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，即致力於維持企業形象，並恪遵各項法令規定，截至公開說明書刊印日止，並未有發生因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，尚無併購之計畫。惟將來若有併購計畫時，將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理，秉持審慎評估之態度，考量合併是否為本公司帶來具體綜效，以確實保障公司利益及股東權益。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

因 12 吋代工客戶產能需求持續攀升，本公司近期之 12 吋產能無法滿足客戶需求。為滿足中長期營運規劃，本公司在充分評估後，已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構 12 吋生產基地。相關投資計畫尚在規劃中，原則以分期、分階段，以公司財務可負擔，最小風險下擴充廠房及產能，同時兼顧公司穩健成長與滿足客戶產能需求。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1)進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司於 108~109 年度及 110 年第三季，並無任一供應商之進貨比重超過 30%，故本公司無進貨集中之情事，本公司與供應商均維持良好且穩定之合作關係，除充分掌握原物料之供貨來源外，並在產品品質上嚴格控管，以確保主要原物料供應無虞。

本公司主要進貨來源如本報告相關章節所揭露訊息，有其不同之產業特性與階段性營運背景考量；針對公司、產業的成長趨勢，進一步適度多元化，分散進貨來源，以期更能維持均衡、穩健的營運結果，為公司持續努力的目標。

(2)銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司於 108~109 年度及 110 年第三季，對單一或集團客戶之營收比重並未超過 30%，本公司無銷貨集中之情事，且隨著營運規模擴大，新產品及新客戶陸續開發，亦有助於降低銷貨集中之風險。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

係因本公司所處半導體產業，對於資金需求龐大，一般而言，股東結構較為多元化；本公司自成立以來，股東為單一法人持有，基於營運及股權分散考量，分別於 108 年度辦理第一次現金增資由母公司力晶科技(股)公司之原股東自行認購，另母公司力晶科技(股)公司於 109 年 06 月 24 日股東會決議通過減資並以持有本公司股票抵充應退還之減資股款案，減資換股後對本公司持股減少至 26.82%，及力晶科技(股)公司配合本公司申請登錄興櫃，提撥股份由輔導券商等認購後，對本公司持股比例降低至 26.59%，又 110 年度為財務調度處分本公司部分持股並認購本公司現金增資新股，持股比例略降至 24.54%，力晶科技(股)公司現雖非為本公司之母公司，係仍為本公司之第一大股東，故對本公司經營權改變之風險仍屬有限。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

12.其他重要風險及因應措施：無。

(二)訴訟或非訟事件

1.公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(四)發行公司於最近一個會計年度或申請上市會計年度內，其子公司符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項重要子公司標準之一者，應增列該子公司之風險事項說明：本公司之子公司並未達重要子公司標準，故不適用。

(五)外國發行公司應增列敘明外國發行公司註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施：本公司非屬外國發行公司，故不適用。

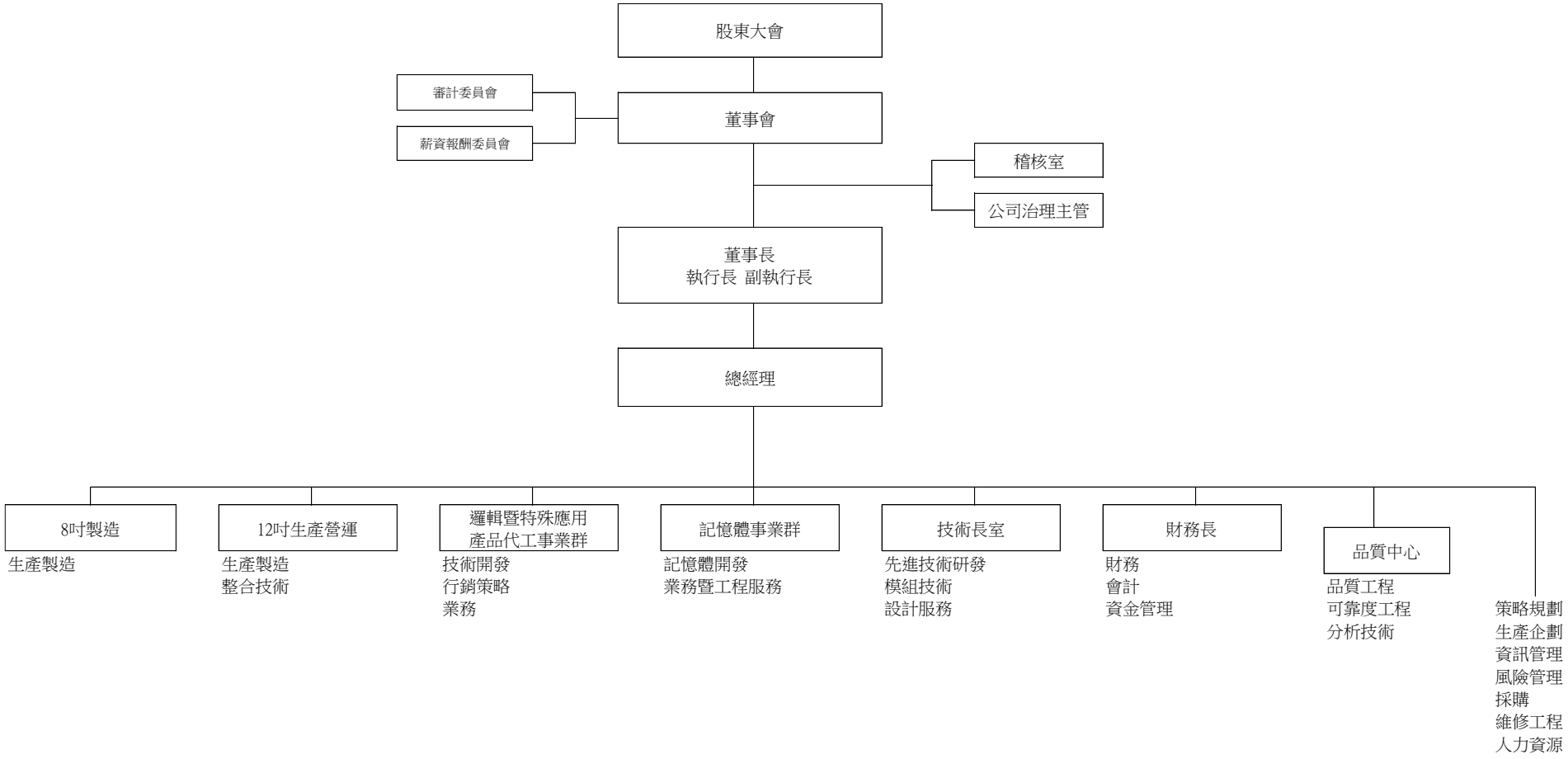
(六)本國發行公司或外國發行人初次申請股票在創新板上市者，應增列敘明擁有之關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式，及因重大技術、產品、政策、經營模式變化、核心技術人員變動等可能導致之風險，並說明所採行之因應措施：本公司非初次申請股票在創新板上市者，故不適用。

(七)其他重要事項：無。

三、公司組織

(一)組織系統

1.組織系統圖



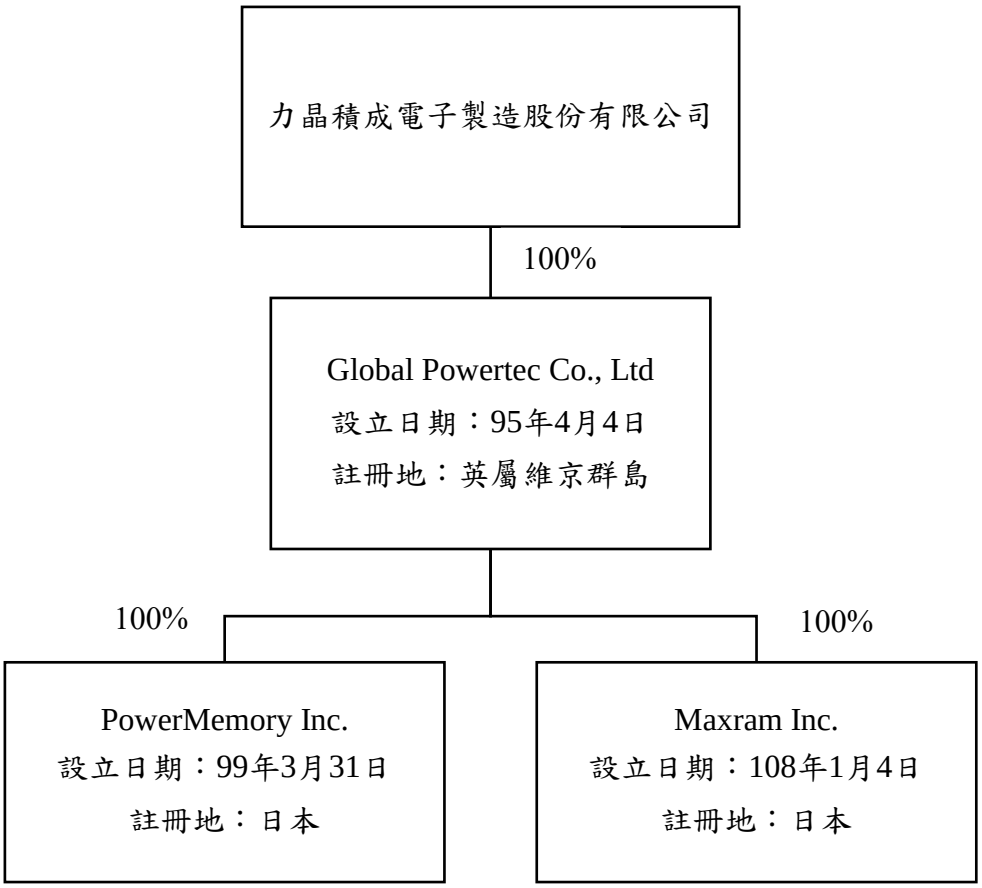
2.各主要部門所營業務

單位名稱	任務職掌
稽核室	檢查、評估內部控制制度之缺失，規劃督導年度查核作業。
策略規劃	協助公司制定經營策略與計畫，整合內外部資源最佳化運用，以執行生產與研發計劃。定期檢視經營績效，管控營運風險，達到公司持續發展與永續經營目標。
8 吋製造	負責本公司 8 吋晶圓代工生產營運規劃，提升製程、設備、製造、整合技術與改善能力，以達營運獲利指標。
12 吋生產營運	負責本公司 12 吋生產經營計畫與營運發展規劃、日常營運與達成獲利營運指標，針對產品製造與代工，成立代工技術平台及導入代工業務，持續進行製程、設備、製造技術之開發及改善與多樣化的代工產品之開發及量產。
邏輯暨特殊 應用產品代工事業群	以自主之製程技術開發能力，利用現有 8 吋及 12 吋廠之資源，推動本公司非記憶體產品線以外之「邏輯暨特殊應用產品晶圓代工」(LSPF)業務，並導入具市場競爭力的產品及客戶，創造合理及穩定成長的股東權益。
記憶體事業群	負責記憶體市場分析與規劃、相關記憶體產品與代工業務開發銷售與客戶服務。結合記憶體的新製程及新產品進行開發評估，以及相關技術開發、量產驗證及品質提升，製造高品質產品，提供客戶最佳產品與銷售服務。
技術長室	建立產品完整設計能力以提供客戶完整的產品線/技術服務，包含邏輯、嵌入式、快閃記憶體元件、關鍵元件、先進製程規劃與評估等，並對於新製程及新產品進行開發評估，以及相關技術開發與量產。藉由提供產品量產所需之相關技術、設計服務及整合，為公司與客戶創造最大利潤。
財務長	配合公司整體營運、規劃、籌集、運用財務資源，並適時提供財會資訊，作為經營管理短、中及長期決策之參考，在審慎運用相關資源下提升財務收益。
品質中心	督導所轄單位確實執行公司交付任務，建立並推廣各項品質系統以確認產品品質，協調各生產單位建立標準化制度以應量產之需。
生產企劃	依據公司營運目標，制訂各廠生產計劃、產銷協調、整合內外部資源，以執行生產計劃，達成公司業績與獲利目標。
資訊管理	建立協同管理的企業資訊系統，快速因應經營管理需求並維持系統穩定運轉及運作機制。
風險管理	擬定公司風險管理策略，有效整合安全衛生環保體系使之成為產品品質一部份。
採購	適時、適量、適價提供公司運作所需之物資，建立採購暨進出口、保稅相關制度。
維修工程	整合公司各廠零組件維修及工程開發製造、零件清洗、協助客戶維修代買等相關業務。
人力資源	適時提供組織所需人力資源、建立及維護公平、合理的工作環境、確保公司人力資產與公司發展同步成長。

(二)關係企業圖

1.關係企業圖

110年09月30日



2.與關係企業間之關係、相互持股比例、股份及實際投資金額

110 年 09 月 30 日；單位：新臺幣仟元；仟股；%

關係企業名稱	與本公司之關係	本公司持有關係企業			關係企業持有本公司		
		股數	比例	實際投資金額	股數	比例	實際投資金額
Global Powertec Co., Ltd	子公司	-	100.00	1	-	-	-
PowerMemory Inc.	孫公司	500	100.00	703,165	-	-	-
Maxram Inc.	孫公司	800	100.00	22,415	-	-	-

(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管與技術及研究發展人員資料

110 年 09 月 30 日；股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
董事長暨執行長	黃崇仁	男	中華民國	108.05.01	115,635,061	3.40	348,350	0.01	-	-	美國紐約大學西奈山醫學院醫學博士 力晶科技(股)公司技術暨策略總監	利翔航太電子(股)公司董事長 智成電子(股)公司董事長 智立投資(股)公司董事長 Global Powertec Co. Ltd.(BVI) 董事長 智仁科技開發(股)公司董事長 宏麗數位創意(股)公司董事長 智合精準醫學科技(股)公司董事長 智高醫學科技(股)公司董事長 財團法人力晶文化基金會董事長 財團法人力晶環境保護基金會董事長 智慧記憶科技(股)公司董事長 飛聖航空(股)公司董事長 力晶科技(股)公司董事長 財團法人力仁教育基金會董事 力宇創業投資(股)公司董事 力世創業投資(股)公司董事 財團法人華聚產業共同標準推動基金會常務董事 力相光學(股)公司董事長 力立企業(股)公司董事 力元投資(股)公司董事 仁典投資(股)公司董事 瑞聖(股)有限公司董事 力晶微元科技(股)公司董事	-	-	-	9,000,000	註1
副執行長暨總經理	謝再居	男	中華民國	108.05.01	1,687,029	0.05	-	-	-	-	美國俄亥俄州辛辛那堤電機博士 美國德州大學(Arlington)電機系副教授兼研究中心主任 力晶科技(股)公司副執行長暨先進技術總監	智成電子(股)公司董事 智慧記憶科技(股)公司董事	-	-	-	2,800,000	-
資深副總	施奕強	男	中華民國	108.05.01	591,181	0.02	-	-	-	-	美國匹茲堡大學電機博士 台積電資深處長 力晶科技(股)公司資深副總經理	-	-	-	-	800,000	-
副總經理兼財務長	邵章榮	男	中華民國	108.05.01	89,000	0.00	-	-	-	-	國立台灣大學國際企業碩士 力晶科技(股)公司總經理特別助理	智仁科技開發(股)公司監察人 PowerMemory Inc.監察人	-	-	-	1,400,000	-

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
											力晶科技(股)公司副總經理						
事業群總經理	顧峻	男	美國	109.06.01	200,000	0.01	86,956	-	-	-	美國耶魯大學應用物理碩士 愛普科技(股)公司總經理 Cypress Semiconductor 特殊DRAM 產品工程處長 Cascade Semiconductor 副總經理 Intel Corporation 微處理器設計工程師	-	-	-	-	1,800,000	-
事業群總經理	朱憲國	男	中華民國	108.05.01	748,699	0.02	-	-	-	-	美國賓州州立大學工業工程碩士 力晶科技(股)公司代工產品事業群副總經理	-	-	-	-	1,800,000	-
副總經理	吳元雄	男	中華民國	109.06.01	754,961	0.02	-	-	-	-	日本亞細亞大學經濟學士 力晶科技(股)公司業務處長 力晶科技(股)公司副總經理 Renesas SP Drivers Inc.董事	Maxram Inc.董事 Powerchip Corp. Japan 董事 智成電子(股)公司董事 PowerMemory Inc.董事 智高醫學科技(股)公司監察人 智慧記憶科技(股)公司監察人	-	-	-	1,500,000	-
副總經理	陳章鑑	男	中華民國	108.05.01	1,346,707	0.04	5,422	-	-	-	國立台灣海洋大學電子工程系學士 工研院電子所駐美西辦事處主任 力晶科技(股)公司採購處長 瑞晶電子(股)公司行政副總經理 力晶科技(股)公司副總經理	-	-	-	-	1,200,000	-
副總經理	劉志能	男	中華民國	108.05.01	1,133,449	0.03	8,957	-	-	-	國立交通大學工業工程碩士 力晶科技(股)公司生產企劃處長 Renesas SP Drivers Inc.董事 力晶科技(股)公司副總經理	智成電子(股)公司監察人	-	-	-	1,200,000	-
副總經理	謝明霖	男	中華民國	108.05.01	230,000	0.01	-	-	-	-	國立台灣大學碩士 力晶科技(股)公司總經理特別助理 力晶科技(股)公司副總經理	力世創業投資(股)公司董事 世仁投資(股)公司董事 愛普科技(股)公司董事 智高醫學科技(股)公司董事 智成電子(股)公司董事 Maxram Inc.董事 智仁科技開發(股)公司董事 富碩投資股份有限公司董事 力信投資(股)公司董事 芯鼎科技(股)公司獨立董事 力宇創業投資(股)公司監察人 力相光學(股)公司監察人 智旺科技(股)公司監察人	-	-	-	1,400,000	-

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
												瑞相科技(股)公司監察人 智慧記憶科技(股)公司監察人 力晶科技(股)公司董事					
副總經理	譚仲民	男	中華民國	108.05.01	199,000	0.01	-	-	-	-	國立台灣大學碩士 力晶科技(股)公司特別助理 力晶科技(股)公司副總經理	世成科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司監察人	-	-	-	1,100,000	-
副總經理	陳冠州	男	中華民國	108.05.01	90,639	-	-	-	-	-	國立台灣大學電機工程所計算機組碩士 工研院電通所系統軟體部經理 華邦電子記憶體產品行銷企劃處經理處長 華邦電子記憶體事業群行銷企劃協理 力積電子(股)公司總經理 力晶科技(股)公司副總經理	智成電子(股)公司董事 Maxram Inc.董事 智慧記憶科技(股)公司董事 凌網科技(股)公司獨立董事	-	-	-	1,000,000	-
副總經理	吳明長	男	中華民國	108.05.01	1,327,726	0.04	79,770	-	-	-	中原大學工業工程系學士 力晶科技(股)公司廠長 力晶科技(股)公司協理	-	-	-	-	1,400,000	-
副總經理	簡文勝	男	中華民國	108.05.01	349,129	0.01	-	-	-	-	國立清華大學材料所碩士 鉅晶電子(股)公司資深副總經理	-	-	-	-	1,200,000	-
副總經理	張守仁	男	中華民國	109.06.01	1,196,211	0.04	-	-	-	-	國立台灣大學電機博士 台灣積體電路製造(股)公司副處長 力晶科技(股)公司協理	-	-	-	-	1,500,000	-
協理	陳俊良	男	中華民國	108.05.01	193,359	0.01	-	-	-	-	國立清華大學核子工程碩士 德州儀器計畫經理 力晶科技(股)公司業務處長 瑞力科技總經理 智安電子總經理 智旺科技總經理 力晶科技(股)公司協理	力晶微元科技(股)公司董事	-	-	-	1,000,000	-
業務協理	龐忠義	男	中華民國	108.05.01	880,286	0.03	-	-	-	-	淡江大學電子計算機系學士 力晶科技(股)公司業務處長 力晶科技(股)公司協理	-	-	-	-	600,000	-
協理	蔡明勳	男	中華民國	108.05.01	138,867	-	-	-	-	-	Stony Brook University 電子工程碩士 力晶科技(股)公司資深技術處長	-	-	-	-	1,000,000	-
協理	林盈禎	男	中華民國	108.05.01	200,544	0.01	-	-	-	-	國立成功大學電機研究所碩士 鉅晶電子(股)公司行銷業務副總經理	-	-	-	-	1,000,000	-
協理	吳德源	男	中華民國	108.11.18	185,347	0.01	-	-	-	-	國立交通大學電子工程所碩士 聯華電子(股)公司技術處長	-	-	-	-	1,000,000	-

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
專案協理	林保全	男	中華民國	108.03.12	50,869	-	-	-	-	-	東海大學工業工程學士 國立交通大學科技管理碩士 晶相光電(股)公司副總經理	-	-	-	-	1,000,000	-
資訊長	劉堅松	男	中華民國	109.01.21	354,648	0.01	-	-	-	-	逢甲大學資訊工程學士 佛州理工大學資訊工程碩士 EDS Senior 工程師 美台電訊AT&T(股)公司MIS 資深副理 元太科技工業(股)公司資訊處長及生產營運中心資訊暨營運處長 羅技電子(股)公司亞太地區資訊處長 慧盟資訊科技(股)公司副總	-	-	-	-	800,000	-
協理	王炳堯	男	中華民國	109.01.21	239,347	0.01	-	-	-	-	逢甲大學電機工程學士 國立清華大學電機工程碩士 合泰半導體(股)公司工程師 力晶科技(股)公司部經理 台灣積體電路(股)公司經理 華邦電子(股)公司 Technology Executive 聯華電子(股)公司資深處長	-	-	-	-	1,000,000	-
協理/公司治理主管	許梅珊	女	中華民國	109.04.09	101,086	-	16,844	-	-	-	台灣科技大學企業管理系學士 新亞建設開發(股)公司代副理兼股務組組長 力晶科技(股)公司資深處長	-	-	-	-	800,000	-
協理	姜建德	男	中華民國	109.04.09	100,165	-	327	-	-	-	國立清華大學材料所碩士 力晶科技(股)公司資深處長	-	-	-	-	700,000	-
會計主管	邱垂源	男	中華民國	108.05.01	50,502	-	-	-	-	-	中原大學會計研究所碩士 力晶科技(股)公司會計處資深處長暨會計主管	-	-	-	-	400,000	-
稽核主管	潘朝陽	男	中華民國	108.05.01	147,623	0.01	-	-	-	-	交通大學電子工程所碩士 力晶科技(股)公司主任 工研院電通所經理 工研院電子所課長	-	-	-	-	206,000	-

註1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司係有董事長兼任執行長之情事，主因應公司組織發展所需，惟本公司已選任五席獨立董事，占全體董事庸次超過半數，並由全數五席獨立董事聘任為審計委員會成員，以強化監督功能。

註2：強制集保對象持有股份為110年7月29日之持股數。

(四)董事及監察人

1.董事及監察人姓名、經(學)歷、持有股份及性質

110 年 09 月 30 日；股；%

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選(就)任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有之股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內之主管、董事、監察人其他關係			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	黃崇仁	男	中華民國	97.04.01	109.05.27	3年	4,212,306	0.14	115,635,061	3.40	348,350	0.01	-	-	美國紐約大學西奈山醫學院醫學博士 力晶科技(股)公司技術暨策略總監	力晶積成電子製造(股)公司執行長 利翔航太電子(股)公司董事長 智成電子(股)公司董事長 智立投資(股)公司董事長 Global Powertec Co. Ltd.(BVI) 董事長 智仁科技開發(股)公司董事長 宏麗數位創意(股)公司董事長 智合精準醫學科技(股)公司董事長 智高醫學科技(股)公司董事長 財團法人力晶文化基金會董事長 財團法人力晶環境保護基金會董事長 智慧記憶科技(股)公司董事長 飛聖航空(股)公司董事長 力晶科技(股)公司董事長 財團法人力仁教育基金會董事 力宇創業投資(股)公司董事 力世創業投資(股)公司董事 財團法人華聚產業共同標準推動基金會常務董事 力相光學(股)公司董事長 力立企業(股)公司董事 力元投資(股)公司董事	-	-	-	註1

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選(就)任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有之股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事、監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
																仁典投資(股)公司董事 瑞聖(股)有限公司董事 力晶微元科技(股)公司董事				
董事	謝再居	男	中華民國	97.04.01	109.05.27	3年	613,480	0.02	1,687,029	0.05	-	-	-	-	美國俄亥俄州辛辛那堤電機博士 美國德州大學(Arlington)電機系副教授兼研究中心主任 力晶科技(股)公司副執行長暨先進技術總監	力晶積成電子製造(股)公司副執行長暨總經理 智成電子(股)公司董事 智慧記憶科技(股)公司董事	-	-	-	-
董事	仁典投資(股)公司	-	中華民國	109.05.27	109.05.27	3年	1,100,000	0.04	16,451,676	0.48	-	-	-	-	-	海悅國際開發(股)公司董事 力晶科技(股)公司董事 智合精準醫學科技(股)公司董事 智高醫學科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司監察人 智豐科技(股)公司董事長/董事 集邦科技(股)公司董事 新相科技(股)公司董事	-	-	-	-
	代表人：邵章榮(註2)	男		109.02.15	109.11.24		-	-	89,000	0.00	-	-	-	-	國立台灣大學國際企業碩士 力晶科技(股)公司總經理特別助理 力晶科技(股)公司副總經理	力晶積成電子製造(股)公司副總經理兼財務長 智仁科技開發(股)公司監察人 PowerMemory Inc.監察人	-	-	-	-
董事	力晶科技(股)公司(註3)	-	中華民國	97.04.01	109.11.24	2.5年	832,792,640	26.82	835,486,370	24.54	-	-	-	-	-	世仁投資(股)公司董事長/董事 力信投資(股)公司董事長/董事 富碩投資(股)公司董事長/董事 力晶微元科技(股)公司董事長/董事 智典國際(股)公司董事 合肥晶合集成電路(股)公司董事長/董事 世成科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司董事 智成電子(股)公司董事長 Poly-Magic Materials Coporation	-	-	-	-

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選(就)任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有之股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內之其他關係人之主管、董事、監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
																董事 力字創業投資(股)公司董事				
	代表人：徐清祥(註 4)	男		110.06.09	110.06.09		-	-	205,032	0.01	-	-	-	-	美國香檳城伊利諾大學電機博士 國立清華大學電子研究所所長 美國紐約州 IBM T. J.華生研究中心研究員	力旺電子股份公司董事長 漢芝電子(股)公司董事長 PUFsecurity USA Corporation 董事長 熵碼科技(股)公司董事長暨總經理 安瀚科技(股)公司董事 宏碁(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 閎康科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 財團法人國家實驗研究院董事	-	-	-	-
獨立董事	吳重雨(註 3)	男	中華民國	109.11.24	109.11.24	2.5年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電子工程博士 國立交通大學前校長暨榮譽退休講座教授 晶焱科技(股)公司獨立董事	晶神醫創(股)公司董事長暨技術長 聯發科技(股)公司獨立董事 創意電子(股)公司獨立董事 通嘉科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	張嘉臨(註 3)	男	中華民國	109.11.24	109.11.24	2.5年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國普林斯頓電機工程博士 美國賓州大學華頓商學院 MBA 美國摩托羅拉公司半導體工程師 美商高盛投資銀行全球合夥人 宏達國際電子(股)公司總經理及財務長	前進智能(股)公司董事長 前進福臨有限公司董事	-	-	-	-
獨立董事	林憲銘(註 3)	男	中華民國	109.11.24	109.11.24	2.5年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電子計算機與控制工程學士 宏碁電腦(股)公司總經理	緯創資通(股)公司董事長兼策略長 緯穎科技服務(股)公司董事長 遊戲橘子數位科技(股)公司董事 台灣典範半導體(股)公司獨立董事	-	-	-	-

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選(就)任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有之股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內之關係之其他主管、董事、監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
																義隆電子(股)公司獨立董事 緯創數技投資控股(股)公司董事長				
獨立董事	林本堅 (註 5)	男	中華民國	110.07.02	110.07.02	2年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國俄亥俄州立大學電機工程學系博士 國立台灣大學電機工程學系學士 美國國際商用機器公司研究員、研發經理、部經理、幕僚 台灣積體電路製造股份有限公司資深處長、傑出科技院士/副總經理 美國領創公司總經理	國立清華大學特聘研究講座教授 國立交通大學特聘研究講座教授 國立臺灣大學特聘研究講座教授 國立清華大學台積電聯合研發中心主任	-	-	-	-
獨立董事	葉疏 (註 5)	男	中華民國	110.07.02	110.07.02	2年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國加州大學洛杉磯分校會計學博士 中華電信(股)公司財務長暨執行副總經理 中華電信(股)公司獨立董事 愛普科技(股)公司獨立董事兼審計及薪酬委員	國立台灣大學會計系教授 捷敏股份有限公司獨立董事兼審計及薪酬委員 龍巖(股)公司獨立董事兼審計及薪酬委員	-	-	-	-

註1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司係有董事長兼任執行長之情事，主因應公司組織發展所需，惟本公司已選任五席獨立董事，占全體董事庸次超過半數，並由全數五席獨立董事聘任為審計委員會成員，以強化監督功能。

註2：法人董事仁典投資(股)公司於110年6月9日改派董事代表人(舊任代表人為謝明霖先生；新任代表人為邵章榮先生)。

註3：本公司於109年11月24日股東臨時會補選董事(含獨立董事)後新任。

註4：法人董事力晶科技(股)公司於110年6月9日改派董事代表人(舊任代表人為童貴聰先生；新任代表人為徐清祥先生)。

註5：本公司於110年7月2日股東常會補選董事後新任。

註6：強制集保對象持有股數為110年7月29日之持股數。

2.法人股東之主要股東

110 年 02 月 28 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
仁典投資股份有限公司	黃崇仁(99.92%) 黃毓秀(0.08%)
力晶科技股份有限公司	黃崇仁(4.74%) 陳嘉益(1.85%) 瑞聖股份有限公司(1.25%) 智豐科技股份有限公司(1.22%) 世成科技股份有限公司(0.75%) 仁典投資股份有限公司(0.73%) 智翔投資股份有限公司(0.69%) 匯豐託管凱基代理人（香港）有限公司專戶(0.67%) 元隆投資有限公司(0.63%) 智立投資股份有限公司(0.60%)

3.主要股東為法人者其主要股東

110 年 02 月 28 日

法人名稱	法人之主要股東
瑞聖股份有限公司	力元投資股份有限公司(100%)
智豐科技股份有限公司	智立投資股份有限公司(23.90%) 智仁科技開發股份有限公司(9.13%) 世仁投資股份有限公司(8.51%) 瑞聖股份有限公司(5.94%) 世成科技股份有限公司(5.13%) 元隆投資有限公司(4.85%) 力信投資股份有限公司(4.75%) 力元投資股份有限公司(4.57%) 仁典投資股份有限公司(4.48%) 力晶科技股份有限公司(4.13%)
世成科技股份有限公司	力晶科技股份有限公司(24.54%) 智翔投資股份有限公司(21.03%) 力信投資股份有限公司(20.40%) 力宇創業投資股份有限公司(8.15%) 力世創業投資股份有限公司(5.20%) 力新國際科技股份有限公司(2.77%) 智仁科技開發股份有限公司(2.72%) 利翔航太電子股份有限公司(1.65%) 瑞相科技股份有限公司(1.16%) 黃毓秀(1.05%)
仁典投資股份有限公司	黃崇仁(99.92%) 黃毓秀(0.08%)
智翔投資股份有限公司	世成科技股份有限公司(36.39%) 力晶科技股份有限公司(26.37%) 力信投資股份有限公司(21.53%) 力新國際科技股份有限公司(4.08%) 力宇創業投資股份有限公司(3.46%) 智仁科技開發股份有限公司(1.02%) 力世創業投資股份有限公司(0.88%) 智豐科技股份有限公司(0.82%) 智成電子股份有限公司(0.42%) 悅山投資股份有限公司(0.26%)
匯豐託管凱基代理人(香港)有限公司專戶	無

法人名稱	法人之主要股東
元隆投資有限公司	力立企業股份有限公司(100%)
智立投資股份有限公司	智豐科技股份有限公司(77.36%) 力信投資股份有限公司(7.53%) 世仁投資股份有限公司(4.64%) 智仁科技開發股份有限公司(3.95%) 力晶科技股份有限公司(3.30%) 智翔投資股份有限公司(2.54%) 力新國際科技股份有限公司(0.57%) 智安電子股份有限公司(0.09%)

4.董事、監察人所具備之專業知識及獨立性之情形

條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形(註)												兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他公司業務所需之國家考試及格領書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
黃崇仁			✓				✓		✓				✓	✓	✓	無
謝再居	✓		✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	無
邵章榮			✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		無
徐清祥			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2
吳重雨	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
張嘉臨			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
林憲銘			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
林本堅	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
葉疏	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

註：各董事、監察人符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓"

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董

事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(五)發起人資料：不適用。

(六)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.最近年度(109 年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1)董事(含獨立董事)之酬金

單位：新臺幣仟元；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取自公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	力晶科技(股)公司																					
	代表人：黃崇仁																					
	黃崇仁(註 2)																					
副董事長	力晶科技(股)公司(註 2、7)																					
	代表人：蔡國智(註 3)																					
董事	代表人：王其國(註 4、7)																					
	代表人：童貴聰(註 8、9)																					
董事	力晶科技(股)公司																					
	力元投資(股)公司(註 2)																					
	代表人：邵章榮(註 2)	740	740	-	-	55,000	55,000	1,068	1,068	1.49%	1.49%	84,218	84,218	24,435	24,435	49,619	-	49,619	-	5.65%	5.65%	319,561
董事	力晶科技(股)公司																					
	智翔投資(股)公司(註 2)																					
	代表人：童貴聰(註 2、5)																					
	代表人：朱憲國(註 10、14)																					
董事	力晶科技(股)公司																					
	力立企業(股)公司(註 2、10)																					
	代表人：朱憲國(註 2、10)																					

職稱	姓名	董事酬金								A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取自公司以外轉投資業母公司或子公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事	力晶科技(股)公司																					
	仁典投資(股)公司(註 2)																					
	代表人：陳瑞隆(註 5)																					
	代表人：顧峻(註 6、13)																					
	代表人：謝明霖(註 10、14)																					
董事	力晶科技(股)公司																					
	代表人：謝再居																					
	謝再居(註 2)																					
董事	力晶科技(股)公司																					
	智成電子(股)公司(註 2、11)																					
	代表人：吳元雄(註 2、11)																					
董事	力晶科技(股)公司																					
	智特(股)公司(註 2、12)																					
	代表人：謝明霖(註 1、2、12)																					
獨立董事	吳重雨(註 9)																					
獨立董事	張嘉臨(註 9)																					
獨立董事	林憲銘(註 9)																					

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事酬金係包括參加董事會議及功能性委員會之車馬費及固定報酬。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金： 1,770(仟元)

註1：謝明霖先生於109年02月10日就任法人董事代表人乙職

註2：本公司於109年05月27日改選第八屆董監事。

註3：蔡國智先生於109年05月27日辭任法人董事代表人乙職。

註4：王其國先生於109年05月28日就任法人董事代表人乙職。

註5：陳瑞隆先生於109年08月12日辭任法人董事代表人乙職。

註6：顧峻先生係於109年08月13日就任法人董事代表人乙職。

註7：力晶科技(股)公司於109年11月23日辭任法人董事乙職，法人董事代表人王其國先生同日當然解職。

註8：童貴聰先生於109年11年23月辭任法人董事代表人乙職。
註9：本公司於109年11月24日補選第八屆董事(含獨立董事)。
註10：力立企業(股)公司於109年11月24日辭任法人董事乙職，法人董事代表人朱憲國先生同日當然解職。
註11：智成電子(股)公司於109年11月24日辭任法人董事乙職，法人董事代表人吳元雄先生同日當然解職。
註12：智特(股)公司於109年11月24日辭任法人董事乙職，法人董事代表人謝明霖先生同日當然解職。
註13：顧峻先生於109年11月24日辭任法人董事代表人乙職，股權變動情形為辭任當時之資訊。
註 14：朱憲國先生及謝明霖於 109 年 11 月 24 日就任法人董事代表人乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	吳重雨、張嘉臨、林憲銘、力元投資(股)公司代表人:邵章榮、智翔投資(股)公司代表人：童貴聰及朱憲國、智成電子(股)公司代表人：吳元雄、仁典投資(股)公司代表人：陳瑞隆、顧峻及謝明霖、力晶科技(股)公司代表人：王其國及蔡國智	吳重雨、張嘉臨、林憲銘、力元投資(股)公司代表人：邵章榮、智翔投資(股)公司代表人：童貴聰及朱憲國、智成電子(股)公司代表人：吳元雄、仁典投資(股)公司代表人：陳瑞隆、顧峻及謝明霖、力晶科技(股)公司代表人：王其國及蔡國智	吳重雨、張嘉臨及林憲銘	吳重雨、張嘉臨及林憲銘
1,000,000 元(含)～2,000,000 元(不含)	-	-	仁典投資(股)公司代表人：陳瑞隆	仁典投資(股)公司代表人：陳瑞隆
2,000,000 元(含)～3,500,000 元(不含)	力元投資(股)公司、智翔投資(股)公司、仁典投資(股)公司、力立企業(股)公司、智成電子(股)公司及智特(股)公司	力元投資(股)公司、智翔投資(股)公司、仁典投資(股)公司、力立企業(股)公司、智成電子(股)公司及智特(股)公司	力元投資(股)公司、智翔投資(股)公司、仁典投資(股)公司、力立企業(股)公司、智成電子(股)公司及智特(股)公司及仁典投資(股)公司代表人：顧峻	力元投資(股)公司、智翔投資(股)公司、仁典投資(股)公司、力立企業(股)公司、智成電子(股)公司及智特(股)公司及仁典投資(股)公司代表人：顧峻
3,500,000 元(含)～5,000,000 元(不含)	謝再居	謝再居	-	-
5,000,000 元(含)～10,000,000 元(不含)	-	-	力晶科技(股)公司代表人：王其國	力晶科技(股)公司代表人：王其國
10,000,000 元(含)～15,000,000 元(不含)	黃崇仁	黃崇仁	力元投資(股)公司代表人：邵章榮、仁典投資(股)公司代表人：謝明霖及智成電子(股)公司代表人：吳元雄	力元投資(股)公司代表人：邵章榮、仁典投資(股)公司代表人：謝明霖及智成電子(股)公司代表人：吳元雄
15,000,000 元(含)～30,000,000 元(不含)	力晶科技(股)公司	力晶科技(股)公司	力晶科技(股)公司、力晶	力晶科技(股)公司、力晶

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
			科技(股)公司代表人：蔡國智、智翔投資(股)公司代表人：童貴聰及朱憲國	科技(股)公司代表人：蔡國智、智翔投資(股)公司代表人：童貴聰及朱憲國
30,000,000 元(含)～50,000,000 元(不含)	-	-	謝再居	謝再居
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	黃崇仁	黃崇仁
總計	21 人	21 人	21 人	21 人

(2)監察人之酬金

單位：新臺幣仟元；%

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例		領取來自以子公司投資母公司轉投資或酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
監察人	黃崇恆(註 1、2)	-	-	5,000	5,000	276	276	0.14%	0.14%	360
監察人	陳錦隆(註 1、2)									
監察人	元隆投資有限公司(註 1、2) 代表人：林榮生(註 1、2)									

註 1：109 年 05 月 27 日改選第八屆董監事。

註 2：109 年 11 月 24 日股東臨時會補選董事(含獨立董事)，並成立審計委員會替代監察人職責，於該日卸任監察人職務。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	元隆投資有限公司及元隆投資有限公司代表人：林榮生	元隆投資有限公司及元隆投資有限公司代表人：林榮生
1,000,000 元(含)～2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)～3,500,000 元(不含)	黃崇恆及陳錦隆	黃崇恆及陳錦隆
3,500,000 元(含)～5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)～10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含)～15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)～30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)～50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	4	4

(3)總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣仟元；股；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		領自司轉事母酬無來公外資或司有取子以投業公金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
執行長	黃崇仁	127,630	127,630	38,227	38,227	10,711	10,711	63,400	-	63,400	-	6.30%	6.30%	344,502
副執行長暨總經理	謝再居													
國際策略合作總監	蔡國智(註 1)													
副總經理	吳元雄(註 4)													
事業群總經理	顧峻(註 5)													
事業群總經理	朱憲國													
資深副總	童貴聰(註 6)													
資深副總	施奕強													
副總經理兼財務長	邵章榮													
副總經理	陳章鑑													
副總經理	劉志能													
副總經理	謝明霖													
副總經理	譚仲民													
副總經理	陳冠州													
副總經理	吳明長													
副總經理	簡文勝													
副總經理	徐震球(註 2)													
副總經理	張守仁(註 3)													

註1：蔡國智先生係於109年04月07日辭任國際策略合作總監乙職。
註2：徐震球先生係於109年04月10日辭任副總經理乙職。
註3：張守仁先生係於109年06月01日就任副總經理乙職。
註4：吳元雄先生係於109年06月01日就任事業群共同總經理兼對日策略合作辦公室副總經理乙職。
註5：顧峻先生係於109年06月01日就任事業群共同總經理乙職。
註6：童貴聰先生係於110年01月06日申請退休並卸任資深副總經理乙職。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	顧峻、施奕強、陳冠州	顧峻、施奕強、陳冠州
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	吳元雄、邵章榮、陳章鑑、劉志能、謝明霖、譚仲民、吳明長、簡文勝	吳元雄、邵章榮、陳章鑑、劉志能、謝明霖、譚仲民、吳明長、簡文勝
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	蔡國智、童貴聰、徐震球、朱憲國、張守仁	蔡國智、童貴聰、徐震球、朱憲國、張守仁
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	謝再居	謝再居
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	黃崇仁	黃崇仁
總計	18	18

(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

109年12月31日；單位：新臺幣仟元；%

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
執行長	黃崇仁	-	72,977	72,977	1.92%
副執行長暨總經理	謝再居				
國際策略合作總監	蔡國智(註 3)				
事業群共同總經理兼對日策略合作辦公室副總經理	吳元雄(註 6)				
事業群共同總經理	顧峻(註 7)				
事業群總經理	朱憲國				
資深副總	童貴聰(註 8)				
資深副總	施奕強				
副總經理兼財務長	邵章榮				
副總經理	陳章鑑				
副總經理	劉志能				
副總經理	謝明霖				
副總經理	譚仲民				
副總經理	陳冠州				
副總經理	吳明長				
副總經理	簡文勝				
副總經理	徐震球(註 4)				
副總經理	林盈禎				
副總經理	張守仁(註 5)				
協理	陳俊良				
業務協理	龐忠義				
技術協理	越川康二				
協理	蔡明勳				
專案協理	林保全				
協理	林盈禎				
協理暨品質長	洪潔倫				

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
協理	吳德源				
協理	王炳堯(註 1)				
資訊長	劉堅松(註 2)				
會計主管	邱垂源				

註 1：王炳堯先生係於 109 年 01 月 21 日就任協理乙職。
註 2：劉堅松先生係於 109 年 01 月 21 日就任資訊長乙職。
註 3：蔡國智先生係於 109 年 04 月 07 日辭任國際策略合作總監乙職。
註 4：徐震球先生係於 109 年 04 月 10 日辭任副總經理乙職。
註 5：張守仁先生係於 109 年 06 月 01 日就任副總經理乙職。
註 6：吳元雄先生係於 109 年 06 月 01 日就任事業群共同總經理兼對日策略合作辦公室副總經理乙職。
註 7：顧峻先生係於 109 年 06 月 01 日就任事業群共同總經理乙職。
註 8：童貴聰先生係於 110 年 01 月 06 日申請退休並卸任資深副總經理乙職。

2.分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

(1)最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析

職稱	108 年度 酬金總額占稅後純益比例		109 年度 酬金總額占稅後純益比例	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	(0.03%)	(0.03%)	1.49%	1.49%
監察人	0.00%	0.00%	註	註
總經理及副總經理	(3.51%)	(3.51%)	6.30%	6.30%

註：本公司於 109 年 11 月 24 日成立審計委員會，替代監察人職權，故不適用。

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事酬金政策係訂於公司章程,公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利,應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。董事酬勞係經薪資報酬委員會審核後提交董事會核准,並提案至股東會報告。

經理人之酬金(含薪資、獎金及員工獎酬),係依據經理人對公司營運參與程度及貢獻之價值,以每年薪資調查報告為基礎,參酌同業薪資水準支領經理人薪資,並經薪資報酬委員會審核後提交董事會核准。

本公司支付董事及經理人酬金,皆已併同考量公司未來的營運發展與經營風險,同時評估與其經營績效呈正相關,以謀永續經營與風險控管之平衡。

(七)發行公司之非董事,而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者,應增列敘明上開人士之姓名、經(學)歷、持有股份、目前兼任發行公司及其他公司之職務、與發行公司董事之關係及對發行公司實質控制情形,另外國發行公司尚應敘明上開人士依註冊地國法令規定之法律責任

本公司除依法選任之董事外,並無其他非董事,而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務之情事。

四、資本及股份

(一)股份種類

110 年 08 月 31 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	3,405,196,242	1,594,803,758	5,000,000,000	註

註：非上市(櫃)股票

(二)股本形成經過

1.截至公開說明書刊印日止股本變動情形

單位：股；新臺幣元

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
97.04	10	1,000,000,000	10,000,000,000	500,000,000	5,000,000,000	原始投資	無	註 1
103.08	10	1,000,000,000	10,000,000,000	300,000,000	3,000,000,000	減資退還股款 155,642 仟股；減資彌補虧損 44,358 仟股	無	註 2
104.05	10	1,000,000,000	10,000,000,000	250,000,000	2,500,000,000	減資退還股款 50,000 仟股	無	註 3
106.06	10	1,000,000,000	10,000,000,000	306,364,239	3,063,642,390	盈餘轉增資 56,364 仟股	無	註 4
107.06	10	1,000,000,000	10,000,000,000	358,667,443	3,586,674,430	盈餘轉增資 52,303 仟股	無	註 5
108.01	10	5,000,000,000	50,000,000,000	358,667,443	3,586,674,430	增加核定股本 4,000,000 仟股	無	註 6
108.05	10	5,000,000,000	50,000,000,000	2,705,196,569	27,051,965,690	盈餘轉增資 85,711 仟股及收購發行新股 2,260,818 仟股	無	註 7
108.09	10.1	5,000,000,000	50,000,000,000	3,105,196,569	31,051,965,690	現金增資 400,000 仟股	無	註 8
110.03	10	5,000,000,000	50,000,000,000	3,105,196,242	31,051,962,420	註銷股東拋棄持股	無	註 9
110.06	40	5,000,000,000	50,000,000,000	3,405,196,242	34,051,962,420	現金增資 300,000 仟股	無	註 10

註 1：園商字第 0970009463 號函核准。
註 2：竹商字第 1030022967 號函核准。
註 3：竹商字第 1040015391 號函核准。
註 4：竹商字第 1060015753 號函核准。
註 5：竹商字第 1070017102 號函核准。
註 6：竹商字第 1080001490 號函核准。
註 7：竹商字第 1080012910 號函核准。
註 8：竹商字第 1080028229 號函核准。

註 9：竹商字第 1100007897 號函核准。
註 10：竹商字第 1100017189 號函核准。

2.最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股辦理情形：無。

(三)最近股權分散情形

1.股東結構

110 年 08 月 31 日；單位：股；人；%

股東結構 / 數量	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構或外國人	個人	合計
人數	3	1	443	455	321,694	322,596
持有股數	10,571	6,400,951	1,103,002,545	219,584,845	2,076,197,330	3,405,196,242
持股比例	-	0.19%	32.39%	6.45%	60.97%	100.00%

2.股數分散情形

110 年 08 月 31 日；單位：股；人；%

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	137,538	39,293,202	1.15%
1,000 至 5,000	131,727	277,664,771	8.15%
5,001 至 10,000	24,386	174,607,530	5.13%
10,001 至 15,000	9,693	118,026,103	3.47%
15,001 至 20,000	4,459	78,154,507	2.30%
20,001 至 30,000	5,030	122,932,492	3.61%
30,001 至 40,000	2,376	82,250,371	2.42%
30,001 至 50,000	1,595	71,562,302	2.10%
50,001 至 100,000	2,992	207,035,049	6.08%
100,001 至 200,000	1,549	211,925,683	6.22%
200,001 至 400,000	694	190,343,532	5.59%
400,001 至 600,000	235	115,295,021	3.39%
600,001 至 800,000	92	64,300,835	1.89%
800,001 至 1,000,000	68	61,398,471	1.80%
1,000,001 以上	162	1,590,406,373	46.70%
合計	322,596	3,405,196,242	100.00%

3.主要股東名單

110 年 08 月 31 日；單位：股；人；%

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
力晶科技股份有限公司	835,486,370	24.54
黃崇仁	115,635,061	3.40
花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶	76,921,217	2.26
智豐科技股份有限公司	33,896,376	1.00
大通託管 JP 摩根證券有限公司投資專戶	30,760,607	0.90
瑞聖股份有限公司	28,368,491	0.83
匯豐託管卡登薩主基金	20,492,746	0.60
智翔投資股份有限公司	18,301,213	0.54
仁典投資股份有限公司	16,451,676	0.48
陳嘉益	15,103,000	0.44

4.最近二年度及當年度董事、監察人及持股超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形

(1)董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形

單位：股

職稱	姓名	108 年度		109 年度		110 年 09 月 30 日止	
		可認股數	實認股數	可認股數	實認股數	可認股數	實認股數
董事暨持股比例超過百分之十之股東	力晶科技(股)公司	346,000,000	-	-	-	-	-

(2)放棄現金增資認股洽關係人認購情形：

年度	認購人姓名	與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係	認購股數(股)	價格(元/每股)
108	智翔投資股份有限公司	為法人董事力晶科技(股)公司之關係人	2,384,000	10.1
108	智成電子股份有限公司	關聯企業、董事長同一人	1,900,000	10.1
108	仁典投資股份有限公司	法人董事代表人及及其二等親持股 100%	1,100,000	10.1
108	元隆投資有限公司	力立企業股份有限公司持股 100%	1,000,000	10.1
108	利翔航太電子股份有限公司	董事長同一人	1,000,000	10.1
108	力元投資股份有限公司	法人董事代表人及其二等親合計持股逾 50%	100,000	10.1
108	力立企業股份有限公司	法人董事代表人及其二等親合計持股 100%	100,000	10.1
108	智特股份有限公司	力元投資股份有限公司持股逾 50%	50,000	10.1
108	黃毓秀	法人董事代表人之二親等	500,000	10.1
108	黃美彌	法人董事代表人之二親等	100,000	10.1
108	陳瑞隆	主要管理階層	300,000	10.1
108	朱憲國	主要管理階層	214,000	10.1
108	黃崇仁	主要管理階層	212,306	10.1
108	謝明霖	主要管理階層	200,000	10.1

年度	認購人姓名	與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係	認購股數(股)	價格(元/每股)
108	吳元雄	主要管理階層	200,000	10.1
108	陳章鑑	主要管理階層	200,000	10.1
108	吳明長	主要管理階層	200,000	10.1
108	譚仲民	主要管理階層	120,000	10.1
108	簡文勝	主要管理階層	100,000	10.1
108	張守仁	主要管理階層	100,000	10.1
108	蔡明勳	主要管理階層	100,000	10.1
108	林盈禎	主要管理階層	80,000	10.1
108	邵章榮	主要管理階層	50,000	10.1
108	劉志能	主要管理階層	50,000	10.1
108	龐忠義	主要管理階層	50,000	10.1
108	邱垂源	主要管理階層	50,000	10.1

5.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五股東股權移轉及股權質押變動情形

(1)董事、監察人、經理人、現任技術股東及技術、研究發展人員及持股比例超過百分之五股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

職稱	姓名	108 年度		109 年度		110 年 09 月 30 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	代表人：黃崇仁	4,212,306	-	101,436,485	-	9,986,270	-
董事長	黃崇仁(註 18)	4,212,306	-	101,436,485	-	9,986,270	-
董事/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	代表人：謝再居	613,480		625,793	-	447,756	-
	謝再居(註 18)	613,480		625,793	-	447,756	-
董事/大股東	力晶科技(股)公司(註 18、26、28)	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	代表人：蔡國智(註 18、19)	-	-	-	-	-	--
	代表人：王其國(註 20、26)	691,608	-	1,068,139	-	-	-
	代表人：童貴聰(註 28、39)	1,136,931	-	3,000,241	-	(30,000)	-
	代表人：徐清祥(註 39)	-	-	-	-	16,401	-
董事/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	仁典投資(股)公司(註 18)	-	-	14,035,619	-	1,316,057	-
	代表人：陳瑞隆(註 18、24)	1,071,856	-	(130,000)	-	-	-
	代表人：顧峻(註 25、32)	-	-	-	-	-	-
	代表人：謝明霖(註 33、39)	-	-	-	-	-	-
	代表人：邵章榮(註 39)	240,000	-	(240,000)	-	89,000	-
董事/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	力元投資(股)公司(註 18、38)	-	-	2,319,957	-	-	-
	代表人：邵章榮(註 18、38)	240,000	-	(240,000)	-	89,000	--

職稱	姓名	108 年度		109 年度		110 年 09 月 30 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	智翔投資(股)公司(註 18、38)	-	-	14,953,202	-	1,464,011	-
	代表人：童貴聰(註 18、27)	1,136,931	-	3,000,241	-	(30,000)	-
	代表人：朱憲國(註 33、38)	430,000	-	38,006	-	-	-
董事/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	力立企業(股)公司(註 18、30)	-	-	6,260,558	-	-	-
	代表人：朱憲國(註 18、30)	430,000	-	38,006	-	-	-
董事/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	智特 (股)公司(註 18、31)	-	-	7,699,783	-	-	-
	代表人：王其國(註 11)	691,608	-	1,068,139	-	-	-
	代表人：謝明霖(註 14、18、31)	-	-	-	-	-	-
董事/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	智成電子(股)公司(註 18、29)	-	-	859,146	-	-	-
	代表人：吳元雄(註 18、29)	737,174	-	144,193	-	-	-
監察人/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	代表人：黃崇恆(註 3)	995,661	-	5,565,404	-	-	-
	黃崇恆(註 1、18、28)	995,661	-	5,565,404	-	-	-
監察人/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	代表人：陳錦隆(註 3)	24,392	-	135,977	-	-	-
	陳錦隆(註 1、18、28)	24,392	-	135,977	-	-	-
監察人/大股東	力晶科技(股)公司	2,346,529,126	-	(1,879,504,929)	-	9,794,730	-
	仁典投資(股)公司(註 2)	-	-	-	-	-	-
	元隆投資有限公司(註 18、28)	-		12,229,227	-	-	-
	代表人：胡競英(註 2、3)	100,000	-	-	-	-	-
	代表人：林榮生(註、18、28)	-	-	53,520	-	-	-
獨立董事	吳重雨(註 28)	-	-	-	-	-	-
獨立董事	張嘉臨(註 28)	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林憲銘(註 28)	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林本堅(註 40)	-	-	-	-	-	-
獨立董事	葉疏(註 40)	-	-	-	-	-	-
董事長暨執行長	黃崇仁(註 4)	4,212,306	-	101,436,485	-	9,986,270	-
副執行長暨總經理	謝再居(註 4)	613,480	-	625,793	-	447,756	-
國際策略合作總監	蔡國智(註 16)	-	-	-	-	-	-
資深副總經理	童貴聰(註 4、36)	1,136,931	-	3,000,241	-	-	-
資深副總經理	施奕強(註 4)	350,000	-	241,181	-	-	-
副總經理兼財務長	邵章榮(註 4)	240,000	-	(240,000)	-	89,000	-
財務長及主辦會計	王宗平(註 5)	-	-		-	-	-
副總經理 副總經理	吳元雄(註 4、22、34)	737,174	-	(235,807)	-	253,594	-
事業群共同總經理 事業群總經理	顧峻(註 23、35)	-	-	-	-	200,000	-
事業群總經理	朱憲國	430,000	-	38,006	-	280,693	-
副總經理	陳章鑑(註 4)	608,870	-	666,907	-	70,930	-
副總經理	劉志能(註 4)	533,267	-	507,672	-	92,510	-
副總經理	謝明霖(註 4)	-	-	-	-	230,000	-
副總經理	譚仲民(註 4)	250,000	-	(250,000)	-	199,000	-

職稱	姓名	108 年度		109 年度		110 年 09 月 30 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
副總經理	陳冠州(註 4)	124,000	-	78,069	-	(111,430)	-
副總經理	吳明長(註 4)	708,787	-	347,127	-	271,812	-
副總經理	簡文勝	250,000	-	(30,000)	-	129,129	-
副總經理	徐震球(註 17)	-	-	-	-	-	-
副總經理	劉蔭(註 6)	-	-		-	-	-
協理 技術長 副總經理	張守仁(註 4、15、21)	498,301	-	426,498	-	271,412	-
協理	陳俊良(註 4)	101,277	-	(61,386)	-	153,468	-
協理	蔡明勳(註 4)	127,352	-	98,847	-	(87,332)	-
協理	林盈禎	280,429	-	(237,608)	-	157,723	-
協理	陳輝煌(註 7)	-	-	-	-	-	-
協理	吳德源(註 10)	-	-	-	-	135,347	-
協理	王炳堯(註 12)	-	-	40,000	-	120,347	-
業務協理	龐忠義(註 4)	383,004	-	411,224	-	86,058	-
技術協理	越川康二(註 4、43)	139,000	-	23,723	-	59,148	-
專案協理	林保全(註 8)	10,000	-	-	-	40,869	-
協理暨品質長	洪潔倫(註 9、37)	100,000	-	44,240	-	-	-
資訊長	劉堅松(註 13)	-	-	29,027	-	101,970	-
會計主管	邱垂源(註 4)	70	-	70	-	50,040	-
協理/公司治理主管	許梅珊(註 41)	-	-	-	-	100,086	-
協理	姜建德(註 41)	-	-	-	-	100,165	-

註 1：黃崇恆先生及陳錦隆先生於 108 年 11 月 13 日就任法人監察人乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 2：仁典投資(股)公司及其代表人胡競英女士於 108 年 11 月 13 日就任法人監察人及法人監察人代表人乙職，另仁典投資(股)公司於 108 年 12 月 31 日辭任法人監察人乙職，法人監察人代表人胡競英女士同日當然解職，股權變動情形為就辭任當時之資訊。

註 3：黃崇恆先生、陳錦隆先生及胡競英女士於 108 年 09 月 30 日解任法人監察人代表人乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。

註 4：黃崇仁先生、謝再居先生、童貴聰先生、施奕強先生、邵章榮先生、吳元雄先生、陳章鑑先生、劉志能先生、謝明霖先生、譚仲民先生、陳冠州先生、吳明長先生、張守仁先生、陳俊良先生、蔡明勳先生、龐忠義先生、越川康二先生及邱垂源先生係於 108 年 05 月 01 日就任經理人乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 5：王宗平先生業於 108 年 04 月 30 日辭任財務長及主辦會計乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。

註 6：劉蔭先生業於 108 年 01 月 31 日辭任副總經理乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。

註 7：陳輝煌先生業於 108 年 04 月 30 日辭任協理乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。

註 8：林保全先生係於 108 年 03 月 12 日就任專案協理乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 9：洪潔倫先生係於 108 年 07 月 01 日就任協理暨品質長乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 10：吳德源先生係於 108 年 11 月 18 日就任協理乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 11：王其國先生業於 108 年 12 月 31 日辭任法人董事代表人乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。

註 12：王炳堯先生係於 109 年 01 月 21 日就任協理乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 13：劉堅松先生係於 109 年 01 月 21 日就任資訊長乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 14：謝明霖先生於 109 年 02 月 10 日就任法人董事代表人乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 15：張守仁先生係於 109 年 04 月 01 日就任技術長乙職。

註 16：蔡國智先生係於 109 年 04 月 07 日辭任國際策略合作總監乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。

註 17：徐震球先生係於 109 年 04 月 10 日辭任副總經理乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。

註 18：本公司於 109 年 05 月 27 日改選第八屆董監事。

註 19：蔡國智先生於 109 年 05 月 27 日辭任法人董事代表人乙職，股權變動情形為辭任當時之資訊。

註 20：王其國先生於 109 年 05 月 28 日就任法人董事代表人乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 21：張守仁先生係於 109 年 06 月 01 日就任副總經理乙職。

註 22：吳元雄先生係於 109 年 06 月 01 日就任事業群共同總經理兼對日策略合作辦公室副總經理乙職。

註 23：顧峻先生係於 109 年 06 月 01 日就任事業群共同總經理乙職。

註 24：陳瑞隆先生於 109 年 08 月 12 日辭任法人董事代表人乙職，股權變動情形為辭任當時之資訊。

註 25：顧峻先生於 109 年 08 月 13 日就任法人董事代表人乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 26：力晶科技(股)公司於 109 年 11 月 23 日辭任法人董事乙職，法人董事代表人王其國先生同日當然解職，股權變動情形為就辭任當時之資訊。

註 27：童貴聰先生於 109 年 11 年 23 月辭任法人董事代表人乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 28：本公司於 109 年 11 月 24 日補選第八屆董事(含獨立董事) ，並由獨立董事代替監察人職責，於該日卸任監察人職務。

註 29：智成電子(股)公司於 109 年 11 月 24 日辭任法人董事乙職，法人董事代表人吳元雄先生同日當然解職，股權變動情形為就辭任當時之資訊。

註 30：力立企業(股)公司於 109 年 11 月 24 日辭任法人董事乙職，法人董事代表人朱憲國先生同日當然解職，股權變動情形為就辭任當時之資訊。

註 31：智特(股)公司於 109 年 11 月 24 日辭任法人董事乙職，法人董事代表人謝明霖先生同日當然解職，股權變動情形為就辭任當時之資訊。

註 32：顧峻先生於 109 年 11 月 24 日辭任法人董事代表人乙職，股權變動情形為辭任當時之資訊。

註 33：朱憲國先生及謝明霖於 109 年 11 月 24 日就任法人董事代表人乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

註 34：吳元雄先生係於 110 年 01 月 01 日就任副總經理乙職。

註 35：顧峻先生係於 110 年 01 月 01 日就任記憶產品事業群總經理乙職。

註 36：童貴聰先生係於 110 年 01 月 06 日申請退休並卸任資深副總經理乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。
註 37：洪潔倫先生係於 110 年 03 月 05 日辭任協理暨品質長乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。
註 38：力元投資(股)公司及智翔投資(股)公司於 110 年 6 月 8 日辭任法人董事乙職，其分別之法人董事代表人邵章榮先生及朱憲國先生同日當然解職，股權變動情形為就辭任當時之資訊。
註 39：力晶科技(股)公司及仁典投資(股)公司分別於 110 年 06 月 09 日改派董事代表人(力晶科技(股)公司由舊任代表人童貴驄先生，改派新任代表人徐清祥先生；仁典投資(股)公司由舊任代表人謝明霖先生，改派新任代表人邵章榮先生)。
註 40：林本堅先生、葉疏先生係於 110 年 07 月 02 日股東會補選第八屆董事。
註 41：許梅珊小姐係於 110 年 04 月 09 日就任協理暨公司治理主管乙職，姜建德先生係於 110 年 04 月 09 日就任公司協理乙職，股權變動情形為解任當時之資訊。
註 42：強制集保對象持有股份為 110 年 7 月 29 日之持股數。
註 43：越川康二先生於 110 年 08 年 01 月辭任技術協理乙職，股權變動情形為就任當時之資訊。

(2)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉之相關人為關係人：無。

(3)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相關人為關係人：無。

6.持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等內之親屬關係之資訊：

110 年 08 月 31 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
力晶科技(股)公司	835,486,370	24.54	-	-	-	-	1.黃崇仁 2.仁典投資(股)公司 3.智翔投資(股)公司	1.黃崇仁先生為力晶科技(股)公司之董事長及監察人黃崇恆先生之二等親 2.仁典投資(股)公司為力晶科技(股)公司之董事 3.智翔投資(股)公司為力晶科技(股)公司之董事	-
黃崇仁	115,635,061	3.40	348,350	0.01	-	-	1.力晶科技(股)公司 2.智豐科技(股)公司 3.瑞聖(股)公司 4.仁典投資(股)公司	1.黃崇仁先生為力晶科技(股)公司之董事長及監察人黃崇恆先生之二等親 2.黃崇仁先生之二等親為智豐科技(股)公司之董事 3.黃崇仁先生及其二等親為瑞聖(股)公司之法人代表人 4.黃崇仁先生及其二等親為仁典投資(股)公司之董事	-
花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	76,912,217	2.26	-	-	-	-	-	-	-
智豐科技	33,896,376	1.00	-	-	-	-	1.黃崇仁	1.黃崇仁先生之二等	-

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
(股)公司							2.仁典投資(股)公司	親為智豐科技(股)公司之法人董事代表人 2.仁典投資(股)公司為智豐科技(股)公司之法人董事	
大通託管 JP 摩根證券有限公司投資專戶	30,760,607	0.90	-	-	-	-	-	-	-
瑞聖股份有限公司	28,368,491	0.83	-	-	-	-	黃崇仁	黃崇仁先生及其二等親為瑞聖(股)公司之法人董事代表人	-
匯豐託管卡登薩主基金	20,492,746	0.60	-	-	-	-	-	-	-
智翔投資(股)公司	18,301,213	0.54	-	-	-	-	力晶科技(股)公司	智翔投資(股)公司為力晶科技(股)公司之法人董事	-
仁典投資(股)公司	16,451,676	0.48	-	-	-	-	1.黃崇仁 2. 力晶科技(股)公司 3. 智豐科技(股)公司	1.黃崇仁先生及其二親等為仁典投資(股)公司之董事 2.仁典投資(股)公司為力晶科技(股)公司之法人董事 3.仁典投資(股)公司為智豐科技(股)公司之法人董事	-
陳嘉益	15,103,000	0.44	-	-	-	-	-	-	-

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股；元

項目＼年度			108 年度	109 年度	當年度截至 110 年 09 月 30 日
每股市價	最高		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	最低		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	平均		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
每股淨值	分配前		9.62	10.7	15.97
	分配後		-	10.21	15.32
每股盈餘	加權平均股數(仟股)(調整前)		2,821,863	3,105,197	3,405,196
	每股盈餘(調整前)		(0.94)	1.23	3.07
	每股盈餘(調整後)		-	-	-
每股股利	現金股利		-	0.68	0.65
	無償配股	盈餘配股	-	-	-
		資本公積配股	-	-	-
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析	本益比		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	本利比		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)
	現金股利殖利率		未上市(櫃)	未上市(櫃)	未上市(櫃)

(五)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策

依本公司章程規定，本公司每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後為之。

本公司公開發行後分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告於股東會。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中現金股利於股利總額之 10%~100%，股票股利於股利總額之 0%~90%。

2.本年度擬(已)議股利分派之情形：本公司 109 年下半年盈餘分派，發放現金股利新臺幣 1,525,866 仟元，每股配發 0.49139101 元，業經 110 年 3 月 9 日董事決議通過在案，已於 110 年 5 月 17 日發放。另本公司 110 年上半年盈餘分派，發放現金股利新臺幣 2,213,378 仟元，每股配發 0.65 元，業經 110 年 8 月 9 日董事決議通過在案，已於 109 年 9 月 17 日發放。

(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(七)員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數及範圍

本公司年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本公司稅前淨利，應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數

額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象包括符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異數之會計處理

(1)本公司 109 年度未以股票分派員工酬勞。

(2)若本公司以股票分派員工酬勞之股數計算基礎，及實際配發金額若與估列數有差異時，其差異數視為會計估計變動，列為 110 年度損益。

3.董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司 110 年 3 月 9 日董事會決議通過擬提撥員工酬勞計新臺幣 482,131 仟元與董監酬勞計新臺幣 60,000 仟元，與 109 年度認列費用金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4.股東會報告分派酬勞情形及結果

本公司於 110 年 7 月 2 日股東常會報告 109 年度員工及董監酬勞分配案，以現金分派員工酬勞新臺幣 482,131 仟元與董監酬勞計新臺幣 60,000 仟元，與本公司 109 年度認列費用金額無差異。

5.前一年度員工分紅、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

本公司 108 年度無分派員工、董事及監察人酬勞，故不適用。

(八)公司買回本公司股份情形：無。

五、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

六、特別股辦理情形：無。

七、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形：

(一)截至公開說明書刊印日止尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響

員工認股權憑證種類	第一次（期）員工認股權憑證		第二次（期）員工認股權憑證	
申報生效日期	109.01.06	109.01.06	109.11.10	109.11.10
發行日期	109.01.21	109.11.16	109.11.16	110.03.09
認股存續期間	109.01.21~115.01.20	109.11.16~115.11.15	109.11.16~115.11.15	110.03.09~116.03.08
發行單位數	138,440,000 股	11,560,000 股	268,969,000 股	926,000 股
發行得認購股數占已發行股份總數比率	4.45833%	0.37228%	8.6619%	0.02982%
得認股期間	111.01.22~115.01.20	111.11.16~115.11.15	111.11.16~115.11.15	112.03.09~116.03.08
	第一階段發行	第二階段發行	第一階段發行	第二階段發行
履約方式	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股
限制認股期間及比率	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%
已執行取得股數	0 股	0 股	0 股	0 股
已執行認股金額	新臺幣 0 元	新臺幣 0 元	新臺幣 0 元	新臺幣 0 元
未執行認股數量	138,440,000 股	11,560,000 股	268,969,000 股	926,000 股
未執行認股者其每股認購價格	新臺幣 10 元	新臺幣 14.7 元	新臺幣 14.7 元	新臺幣 63.0 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	4.45833%	0.37228%	8.6619%	0.02982%
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二年後，得於存續期間陸續執行，對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。		本認股權憑證於發行日屆滿二年後，得於存續期間陸續執行，對原股東權益逐年稀釋，故其稀釋效果尚屬有限。	

註 1：本公司業經金融監督管理委員會 109 年 01 月 06 日金管證發字第 1080341941 號函核准員工認股權憑證計 150,000,000 單位，每單位得認購 1 股，計得認購普通股 150,000,000 股。

註 2：本公司業經金融監督管理委員會 109 年 11 月 10 日金管證發字第 1090372995 號函核准員工認股權憑證計 300,000,000 單位，每單位得認購 1 股，計得認購普通股 300,000,000 股。

(二)截至公開說明書刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

1.第一次（期）員工認股權憑證第一階段發行

單位：股；新臺幣元

身份別	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工	副理	王音嵐	3,266,000	0.11%	-	-	-	-	3,266,000	10	32,660,000	0.11%
	副理	林俊杰										
	副理	廖吉慶										
	副理	林克瑾										
	課長	蔡承翰										
	技術副理	蔡永坤										
	副理	張鴻鐘										
	技術經理	簡財源										
	技術經理	車行遠										
	技術副理	林金榮										
	技術經理	張世昌										
	技術經理	黃文達										
	技術經理	黎恙良										
	技術經理	吳章呈										
	技術經理	朱影璁										
	技術經理	張宜翔										
	技術經理	趙世清										
	技術經理	莊志豪										
	副理	白旻杰										
	副理	陳定遠										
	技術經理	薛宏明										

2.第一次（期）員工認股權憑證第二階段發行

單位：股；新臺幣元

身份別	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工	主任工程師	林佳生	975,000	0.03%	-	-	-	-	975,000	14.8	9,750,000	0.03%
	副理	劉玉城										
	主任工程師	張書記										
	主任工程師	曹博鈞										
	主任工程師	黃孝村										
	主任工程師	黃漢興										
	主任工程師	宋維泰										
	主任工程師	李惠嬌										
	主任工程師	翁程鏞										
	工程師	蔡文章										
	主任管理師	林芝菁										
	主任工程師	陳見秋										
	主任工程師	徐文輝										
	主任工程師	塗崇廉										

3.第二次（期）員工認股權憑證第一階段發行

單位：股；新臺幣元

身份別	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	執行長	黃崇仁	24,300,000	0.78%	-	-	-	-	24,300,000	14.8	243,000,000	0.78%
	副執行暨總經理	謝再居										
	事業群總經理	朱憲國										
	事業群共同總經理	顧峻										
	資深副總經理	童貴聰										
	副總經理	張守仁										
	事業群共同總經理兼對日策略合作辦公室副總經理	吳元雄										
	副總經理	吳明長										
	副總經理	謝明霖										
	副總經理兼財務長	邵章榮										
員工	資深處長	許梅珊	5,800,000	0.19%	-	-	-	-	5,800,000	14.8	58,000,000	0.19%
	廠長	李炯君										
	資深處長	姜建德										
	廠長	白弘吉										
	廠長	楊織森										
	廠長	張德賢										
	資深處長	丁立文										
	日本辦事處代表	黃啓宏										
	專案副處長	黃俊欽										
	專案副處長	陳柏霖										

4.第二次（期）員工認股權憑證第二階段發行

單位：股；新臺幣元

身份別	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工	技術處長	洪至偉	926,000	0.03%	-	-	-	-	926,000	63.6	61,579,000	0.03%
	技術課長	王政平										
	資深工程師	郭直育										
	技術經理	黃任生										
	技術經理	紀吉鴻										
	技術經理	沈士雄										
	技術經理	廖啟民										

(三)最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形：無。

九、限制員工權利新股辦理情形：無。

十、併購辦理情形：無。

十一、受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

貳、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1.業務範圍

(1)本公司所營業務主要內容

①CC01080 電子零組件製造業。

②F401010 國際貿易業。

③I599990 其他設計業。

④F601010 智慧財產權業。

【A.各式積體電路之研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工、銷售。

B.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

C.各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝。(限區外經營)

D.半導體設備零組件維修、開發、製造與銷售。

E.研究、開發、設計及銷售下列產品：

a.特殊應用積體電路技術整合服務

b.矽智財設計與服務】

(2)營業比重

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	108 年度		109 年度		110 年第三季	
	營收金額	百分比	營收金額	百分比	營收金額	百分比
邏輯暨特殊應用產品	16,703,015	46.53	25,657,228	56.16	25,395,715	55.37
記憶體產品(片)	10,809,807	30.11	14,049,468	30.75	13,691,907	29.85
記憶體產品(顆)	8,384,299	23.36	5,977,919	13.09	6,777,522	14.78
合計	35,897,121	100.00	45,684,615	100.00	45,865,144	100.00

(3)公司目前之商品(服務)項目

項目	主要商品(服務)項目
半導體晶圓代工服務	①邏輯暨特殊應用產品晶圓代工：提供 IC 設計公司顯示驅動 IC 產品、電源管理晶片產品、分離式元件產品、CMOS 影像感測器產品、嵌入式非揮發性記憶體產品之晶圓代工服務 ②記憶體產品晶圓代工：提供 IC 設計公司動態隨機存取記憶體產品、快閃記憶體產品之晶圓代工服務

(4)計劃開發之新產品(服務)

本公司計劃開發下一代新產品及服務為

①邏輯暨特殊應用產品晶圓代工服務平台：40 奈米顯示驅動 IC 製程、BSI CMOS 影像感測 IC 製程、25 奈米邏輯製程、40 奈米記憶體整合晶片製程等晶圓代工平台、3D 整合晶片技術平台、第三代半導體功率元件製程等晶圓代工平台。

②記憶體產品晶圓代工服務平台：繼完成提供客戶 30/25 奈米代工平台後，目前更專注開發 25 奈米以下更先進製程，以提供客戶更好的晶圓代工平台，以使客戶產品更具競爭力。

2.產業概況

(1)半導體產業之現況與發展

在 108~109 年各國開始全力支援 5G 商轉，領先推出的國家有南韓、美國、澳洲、英國及中國大陸等國，宣告全球正式邁入 5G 世代，110 年將有更多品牌廠商推出多款 5G 手機。5G 技術以高速傳輸、低延遲、大量連網為特色。除了 5G 基礎建設帶動的商機，也將引發終端設備新一波的升級換機需求。

另隨著運算能力增加及資料傳輸速度的提昇、各種網路及雲端數據蒐集技術逐步成熟的情況下，利用數據發展人工智慧(Artificial Intelligence，AI)成為近年相當重要的科技議題,預估 AI 在終端裝置上的應用,將朝向以下六大方向進行:語音助理、進階攝影、直覺化使用介面、降低功耗以延長電池使用時間、增進連線品質與增加個人安全性防護等。人工智慧(AI) 也逐步往全方位的終端應用發展，包括智慧型手機、智慧穿戴、無人機、智慧家居、智慧工廠、智慧駕駛輔助，智慧行動醫療、公共／安防管理或是基因序列等終端應用都將接軌人工智慧。待 5G 商轉有成及 AI 時代來臨，串連起物聯網、車聯網、智能環境、人像或語音辨識等應用場景及行為習慣，將帶來半導體產業一連串的變化與商機。

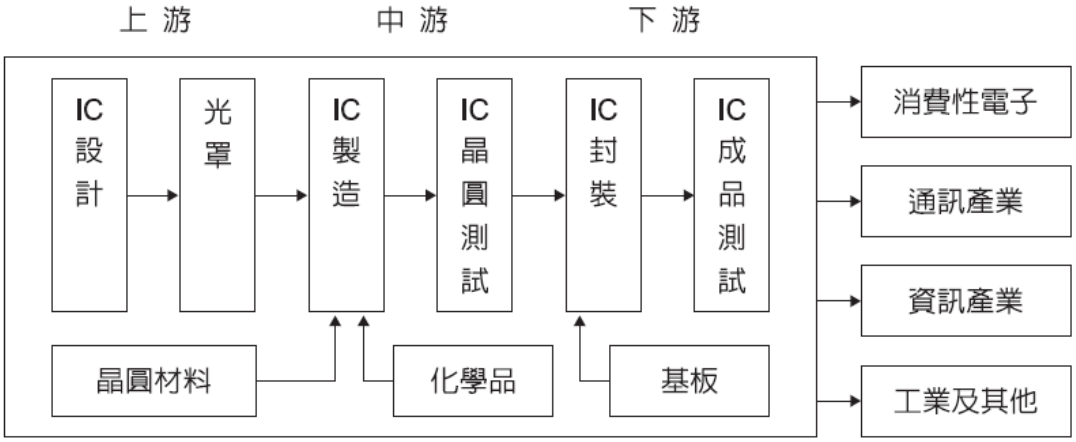
同時因人工智慧技術及效能的提升，物聯網及 5G 行動通訊建設臻於完善，興起許多新型態終端產品，使晶片設計複雜度不斷提昇；除追求晶片功能整合及低功耗外，還需考慮生產效能或是進一步要求半導體製程技術微縮。12 吋晶圓廠已經是半導體的主流供應尺寸，產業新競爭者的進入門檻較過去要更高。加上近幾年，全球 IDM 大廠朝向 Fab-lite 轉型趨勢漸趨明顯，逐步擴大晶圓委外代工訂單，台灣晶圓代工產業成為這波轉型潮最大受惠者。本公司擁有充裕的 12 吋先進製程晶圓產能並專注於利基型的製程，已陸續吸引許多國際 IDM 廠及無晶圓(Fabless)設計公司成為本公司的代工客戶。

有鑑於 AI 及 5G 產業的逐漸成熟，未來終端產品對於高速及低功耗的客製化產品需求更甚，本公司針對此市場趨勢，積極開發更符合客戶需求的特殊邏輯製程及記憶體產品製程，以提供客戶更具市場競爭力的晶圓代工服務。

回顧 109 年，年初因受新冠肺炎疫情肆虐及多國實施封城措施，使各國經濟成長受到影響，失業率攀升，但全球半導體產業卻因新冠肺炎疫情而受惠。新冠肺炎疫情迫使人們行為從「實體轉向虛擬」而帶動宅經濟，各類「宅經濟」相關晶片需求相對穩健。如電視機上盒(STB)晶片、遊戲用 PC、家用遊戲機熱銷; 支援遠距教學及遠端辦公的伺服器晶片、安防監控相關晶片等。109 年下半年則因美中貿易戰升溫，華為禁令更帶動半導體等電子零組件提前拉貨潮。隨著需求逐漸回溫，又因恐新冠肺炎疫情再次升溫而斷料的恐慌心理，使各供應鏈提前備料更加積極，導致上游晶圓代工廠產能吃緊，產能供不應求。展望 110 年，5G、AI、遠距需求及電動車仍為帶動產業成長的主要動能，將帶動晶圓代工、IC 設計、Wi-Fi 6、矽晶圓、設備材料、車用電子、DRAM、被動元件、5G 設備等需求旺。110 年半導體產業將延續 109 年的供需吃緊狀況。

(2)半導體產業上、中、下游之關聯性

半導體產業，泛指所有 IC 設計、生產製造、封裝測試半導體元件相關產品的產業。依功能可將積體電路分為四類產品：記憶體 IC、微元件、邏輯 IC、類比 IC。IC 設計的種類很多，且具有不同特性，對於製程上的要求也不同，故晶圓製造廠及產業鏈間也須與客戶設計及製程需求與時俱進，以符合終端產品規格，並帶動整體產業鏈發展；故半導體產業之上、中、下游之關聯性為



資料來源：工研院經資中心ITIS計畫

(3)終端電子產品之發展趨勢

本公司所提供之晶圓代工服務，其電子終端產品應用，約可歸納為電腦產品(Computer)、通訊應用(Communication)、消費性電子(Consumer)及車用電子(Automotive)產品。目前也正積極發展醫療電子產品應用之 IC。其中隨著智慧型手機產品的普遍及人工智慧相關產品的推出，促使物聯網 (IoT) 產業鏈逐漸成形，更帶動上下游相關元件需求。在消費性終端產品「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，對專業晶圓代工廠而言，能提供客戶客製化製程開發更形重要。

(4)晶圓代工產業競爭情形

本公司提供 12 吋及 8 吋晶圓專業代工服務，包括提供邏輯暨特殊應用產品及記憶體產品晶圓代工服務：

①邏輯暨特殊應用產品晶圓代工業務

107 年 8 月底全球第二大晶圓代工廠 Globalfoundries(GF)宣布退出 7 奈米及以下先進製程的研發與投資，這是繼聯電後第二家宣布放棄 10 奈米以下製程的半導體公司。摩爾定律在 28 奈米節點之後，提升幅度減緩顯示先進邏輯製程不是市場唯一方向，放棄燒錢無止境的先進製程，轉向更有利潤的特殊應用產品市場，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊應用製程(應用於顯示驅動 IC、電源管理晶片、分離式元件、CMOS 影像感測器、嵌入式非揮發性記憶體之製造)及多元代工合作模式，以有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是本公司的競爭策略，28 奈米以上成熟製程市場依然有相當大的規模，包括 IoT、工業、汽車電子等應用。

而有別於一般市面上 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，本公司能提供低成本的 12 吋鋁製程平台，相較同樣技術節點的 8 吋鋁製程，本公司 12 吋鋁製程晶粒成本可大幅降低 30%，大幅提昇客戶產品競爭力。

②記憶體晶圓代工業務

A.動態隨機存取記憶體製程技術

考量到終端電子產品需求朝向功能提升、輕薄化及節能趨勢下，晶片設計更需高度功能整合，其在高效能與低功耗等需求更需較高階製程記憶體產品支持。目前利基型動態隨機存取記憶體代工已導入 25 奈米製程，同時更加速 25 奈米以下新製程平台開發。另有因應人工智慧之類神經網路計算系統所需 AI Memory (記憶體式運算, In-Memory Computing；IMC)，並開發能與邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體，以滿足客戶

不同的客製化記憶體需求，這些都能突顯本公司為惟一提供記憶體產品代工之產業的地位。本公司正與客戶或其他主要供應商密切合作，以切入成長強勁的人工智慧領域需求的半導體市場。

B.NOR 及 NAND Flash 快閃記憶體製程技術

本公司Flash產品瞄準行動應用裝置、消費性電子產品及工業應用市場，提供低功率節能及高可靠度的產品。低容量 NAND Flash 搭配 low-power DRAM 成為入門無線通訊產品主要的記憶體方案。此外，低容量 NAND Flash 也普遍運用於消費性電子產品、通訊產品及汽車聯網或工業應用。目前 28 奈米 NAND Flash 製程已成功進入量產階段。

近年來，許多新興的應用創造更多的 NOR Flash 記憶體需求，如真無線藍芽耳機(TWS)、AMOLED 面板或是 5G 基站設施都有 NOR Flash 需求。因應這些新興應用產品需求，帶動全球 NOR Flash 市場觸底反彈，回到全球年營業額 20 億美金以上。本公司積極開發新一代 48 奈米 NOR Flash 製程，已於 110 年第二季量產；將能提供客戶更高容量、更有成本競爭力並能兼顧品質可靠度要求的 Flash 產品。

3.技術及研發概況

(1)技術層次及研究發展

本公司為能同時提供 DRAM、Flash、顯示驅動 IC(Display Driver IC)、分離式元件(Discrete Devices)、電源管理晶片、CMOS 感測晶片及嵌入式非揮發性記憶體等不同製程的晶圓代工廠。

①邏輯暨特殊應用產品代工業務之各項技術研發分述如下

A.在大面板顯示驅動 IC 代工製程技術方面，為因應高解析度、快速訊號傳輸面板(4K UD TV)的需求，完成核心電壓從 3.3V 到 1.8V 的高壓(18V & 13.5V)平台建置，客戶並以此平台成功大規模量產。在下一代超高解析度(8K TV)上，核心電壓進一步從 1.8V 降到 1.2V，以對應更高頻的訊號傳輸介面。在小尺寸 LCD 驅動 IC 代工製程方面，隨著手機朝極致全螢幕發展，品牌客戶持續優化窄邊框設計，也帶動 TDDI IC(Touch with Display Driver)市場，本公司開發之 80 奈米製程技術主要應用在 TDDI，已進入量產階段。除此，本公司自行開發的 55 奈米 HV 製程平台，亦於 109 年上半年開始量產。40 奈米 HV 製程平台則預計於 109 年年底開發完成，將藉此平台爭取更多的高階 OLED 驅動 IC 客戶與代工業務。未來，本公司將對現有邏輯製程自有技術進行持續開發與改良應用，以最高品質之良率水準與最具成本競爭力之製程技術，協助代工客戶順利開發及量產新世代產品。

B.在 CMOS 感測代工製程技術方面，提供具有競爭力，高性能 0.11 微米技術平臺，為客戶生產高解析度影像感測(CIS，CMOS Image Sensor)晶片，產品應用於手機輔助鏡頭、手機光學屏下指紋、安防監視系統、機器視覺、運動相機與行車紀錄器等高幀率應用之代工產品。現有 FSI 技術 Pixel size 可達 1.75um2，下一階段開發目標是 1.4um2，目前正積極開發 90 奈米及 BSI 技術。同時，已自行開發 CIS 後段彩色濾光膜(color filter)與微鏡頭(micro lens)製程，為客戶提供更全面性的 CIS 晶片代工服務。此外，本公司亦與知名國際大廠共同開發創新生物晶片產品，該產品用於 DNA sequencing(基因序列分析)，已於 107 年通過美國 FDA 驗證且於同年導入量產，並持續積極開發更高階、更高畫素之產品。

C.在嵌入式非揮發性記憶體代工製程技術方面，8 吋廠已進行 0.11 微米 1.5V_5V/5V 製程嵌入式 Flash 製程開發專案，其產品應用在 8bit & 32bit MCU 及物聯網(IoT)相關產品於 109 年下半年開始試產。12 吋廠本公司與知名國際大廠合作，以 0.14 微米製程技術為其代工生產產品，主要用於 NFC(Near Field Communication)、RC(Radio Communication)、RFID(Radio Frequency Identification)、MCU、Power Management IC，已於 105 年陸續進入量產。此外，本公司自行開發 55 奈米 IMC2.0(integrated memory chip)平台於 109 年驗證完畢並已引入客戶進行量產，IMC2.0 可提高客戶產品競爭力，將持續爭取更多 MCU、物聯網(IoT)、Smart card、SIM card 與 Bluetooth 相關應用客戶，40 奈米 IMC 平台規劃中。長期以來，本公司 IMC 技術與製造能力廣受世界大廠肯定，並可以提供從 0.11um 到 55/40nm 嵌入式 Flash 的解決方案，可以滿足客戶不同的需求。

D.在功率半導體分離式元件技術方面，本公司可提供自有平台兼容客製化代工服務，製程含括低中壓 Trench MOSFET 及 Split Gate Trench MOSFET，目前產品應用佈及知名品牌之行動裝置電池管理、智慧型手機快充充電器/PD、NB/PC 主機板、伺服器電源、手工具機及車用領域等。並為國際一級大廠代工高壓 IGBT 提供高品質的晶片，製程能力推升至高功率家電及電動車市場。因應電源走向高功率及節能趨勢，本公司致力於開發前端平台技術，同時與國際大廠合作，穩健佈局第三代半導體及其他分離元件技術，持續提供全方位的高效能分離元件製程代工服務。

E.在類比及電源管理晶片代工製程技術方面，8 吋廠已完成 0.18 微米 Non-Epi BCD 及 Epi BCD 相關製程平台，12 吋廠也已完成 0.15 微米 BCD 相關製程專案量產並持續進行 0.13 微米，80/90 奈米 BCD 製程平台開發。其產品應用在各式類比、音頻及電源管理，電壓操作從 1.2V 到 100V 各式電壓轉換功率管理晶片。12 吋廠 BCD 類比及電源管理晶片代工搭配後段鋁製程技術相當具成本競爭力，目前與多家知名國際大廠合作。本公司長期持續開發類比及電源管理晶片代工製程技術，提供最佳效能及競爭力之技術服務。

②記憶體產品代工業務之各項技術研發分述如下

A.在 NAND Flash 製程技術方面，本公司接受客戶委託設計與代工服務。在產品部分，本公司主推之 40 奈米 low density SLC 1.8V 和 3.3V Dual voltage NAND Flash 高 reliability 產品，讀寫可達 100K 次以上，除錯能力達 1bit ECC。28 奈米之 SLC NAND Flash 技術平台除 S2G/S4G 已進入量產階段，28 奈米也已導入代工客戶，本公司在 NAND Flash 技術也朝下一世代 2y 奈米技術發展。

B.在 NOR Flash 代工製程技術方面，本公司除量產多年的 90 奈米外，48 奈米 NOR Flash 技術平台亦已進入試產階段，預計 110 年導入量產。

C.在 DRAM 代工製程技術方面，DRAM 代工產品除了利基型 DRAM 外，也廣泛應用在 IoT(物聯網)、AI(人工智慧)等 consumer 領域。目前 DRAM 代工 25 奈米 DDR4 已量產，DRAM 技術也朝下一世代技術發展，未來隨著晶片設計在多功能整合、低功耗與效能提升等需求下，本公司正與客戶或其他主要供應商密切合作，開發能與邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體晶片，110 年即將小量試產，將會驅動 DRAM 更多元化的應用需求。

未來本公司之技術研發重點將基於現有基礎，繼續研發各種邏輯與記憶體代工製程技術平台，為客戶提供一流之代工服務，以期在邏輯代工與記憶體代工製程技術上與世界一流廠商並駕齊驅。

(2)研究發展人員與其學經歷

單位：人；年

學歷＼年度	108 年度		109 年度		截至 110 年 9 月 30 日止	
	人數	%	人數	%	人數	%
博士	37	3.34	42	3.61	43	3.67
碩士	685	61.88	743	63.95	763	65.16
大專	366	33.06	357	30.72	345	29.46
高中以下	19	1.72	20	1.72	20	1.71
合計	1,107	100.00	1,162	100.00	1,171	100.00

(3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年第三季
合併研發費用	380,369	389,328	3,453,483	2,962,370	3,234,765	2,951,790
合併營業收入淨額	5,919,892	6,236,632	49,913,779	35,897,121	45,684,615	45,865,144
合併研發費用占營業收入淨額比重	6.43	6.24	6.92	8.25	7.08	6.44

註 1：105 至 106 年度財務資料係未追溯重編。

註 2：107 及 108 年度為自始合併追溯重編之財務資料。

註 3：109 年度及 110 第三季經會計師查核或核閱之財務報告。

(4)最近五年度開發成功之技術或產品

年度	內容說明	應用於
105 年度	◆ 0.15um M1OTP	微控制器 IC
	◆0.18um M1MTP	微控制器 IC
	◆0.35um 50V Gate driver	顯示驅動 IC
	◆0.18um Epi PWM 6V/9V~40V	電源管理 IC
106 年度	◆0.18um Epi PWM 6V/60V~100V	電源管理 IC
	◆0.15um DDI 1.8V_18V	顯示驅動 IC
	◆Double Gate60~100V	分離式元件
	◆0.18um MTP 3.3V/5V	微控制器 IC
	◆0.11um DDI 1.2V/18V	顯示驅動 IC
107 年度	◆ 55nm DDI 1.2V/6V/32V	顯示驅動 IC
	◆ 180nm PMIC Porting in	電源管理 IC
	◆ 1200V IGBT Porting in	分離式元件
	◆ 0.15um DDI 1.8V/9V/18V	顯示驅動 IC
	◆ 0.11um eFlash & 0.11um EEPROM 6V	嵌入式非揮發性記憶體產品
108 年度	◆ 55nm DDI 1.2V/8V/20V	顯示驅動 IC
	◆ 40nm LOGIC 1.2V/2.5V	邏輯 IC 產品
	◆ 80nm DDI 1.2V/6V/32V	顯示驅動 IC
	◆ 0.15um DDI 3.3V/9V/18V	顯示驅動 IC
	◆ Double Gate 30~40V	分離式元件
109 年度	◆ 55nm eFlash 1.2V/2.5V/5V	嵌入式非揮發性記憶體產品
	◆ NOR48	快閃記憶體產品
	◆F38/F25 客製化 DRAM 與邏輯產品堆疊之技術驗證	1.邊緣運算、挖礦 2.high frame-rate CIS, Global Shutter
	◆ 0.65um UMOS	分離式元件

4.長、短期業務發展計劃

(1)邏輯暨特殊應用產品代工業務

本公司以先進技術提供客製化的邏輯暨特殊應用產品專業代工服務。主要包括 TFT-LCD 驅動 IC(TFT-LCD Driver IC)、電源管理 IC (Power Management IC)、分離式元件(Discrete Devices)、快閃記憶體 (Flash)、影像感測 IC (Image Sensor IC)、記憶體整合晶片(Integrated Memory Chip)、RF Chip 及 Bio-tech Chip 等。

①短期業務目標

本公司的 55 奈米 LCD 驅動 IC 高壓製程已成功量產，另亦積極開發 AMOLED 面板驅動 IC 製程，以順應手機市場需求。功率半導體元件則朝高效能之終端電源應用導入具有競爭力的製程，而在其他產線方面，更積極與一些國際大廠合作，開發更多元的產品。

②長期業務目標

除持續開發邏輯暨特殊應用產品代工服務先進製程外，將建立邏輯專業代工平台及開發矽智財，提供專業的晶圓代工服務。同時，本公司亦以所擅長的製造能力，爭取世界級大廠導入其專有技術在本公司生產製造。

同時，為因應產業多變及保有公司應變之彈性，未來本公司除提供產能、製造及設計委託服務外，更可提供營運管理等多元代工模式(Open Foundry)概念，與客戶共創雙贏局面。目前，12 吋的邏輯晶圓代工業務已與 8 吋廠進行整合，未來將提供客戶由 8 吋到 12 吋無縫接軌的的產品規劃、更完善的服務品質及更高性價比的代工產品競爭力。

(2)記憶體晶圓代工業務

本公司以優異先進記憶體技術提供 12 吋晶圓專業利基型記憶體產品及快閃記憶體代工服務。

①短期業務目標

利基型動態隨機存取記憶體代工部分，繼 30 奈米製程成熟量產後，考量到終端電子產品需求朝向功能提升、輕薄化及節能趨勢下發展，晶片設計在功能整合、低功耗與效能提升等複雜因素下，本公司已協助客戶導入 25 奈米製程試產，目前已有超過 20 個以上 25 奈米代工產品開發案投入。本公司也將持續改良製程技術，維持本公司在利基型動態隨機存取記憶體代工的領先優勢。

快閃記憶體部分，本公司具備 NAND Flash 先進製程技術開發及產品設計能力，主要產品為 1Gb~4Gb SLC 快閃記憶體產品。應用領域涵蓋消費性電子、無線通訊產品及工規產品，或智能家電、智慧電錶無線連接等應用市場。隨著這些應用市場的穩定成長，預期全球 SLC 快閃記憶體市場也將逐年穩定成長。同時本公司已順利開發並量產 28 奈米 NAND Flash，面對未來全球新的記憶體產業競爭態勢，將能維持一定的競爭優勢。同時本公司正積極開發新一代 48 奈米 NOR Flash 製程，已於 109 年進入試產階段，並於 110 年進入量產；將能提供客戶更高容量、更有成本競爭力並能兼顧品質可靠度要求的 Flash 產品。

②長期業務目標

在動態隨機存取記憶體產品代工部份，除持續提供先進製程強化競爭力外，將配合客戶需求，與客戶合作生產客製化產品，提昇產品的生命週期，以求追求長期穩定成長。

而快閃記憶體部分(NOR / NAND Flash)部分，將持續開發下一世代先進製程技術，以提高產品競爭優勢。目前也正積極開發大中華地區的新市場及新客戶，以建立長期且穩定的產品出海口。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度		108 年度		109 年度		110 年第三季	
		銷售額	%	銷售額	%	銷售額	%
內銷		23,480,915	65.41	32,938,268	72.10	32,214,278	70.24
外銷	亞洲	5,114,172	14.25	9,367,146	20.50	10,242,094	22.33
	美洲	387,009	1.08	740,317	1.62	774,930	1.69
	歐洲	6,915,025	19.26	2,638,884	5.78	2,633,842	5.74
	小計	12,416,206	34.59	12,746,347	27.90	13,650,866	29.76
合計		35,897,121	100.00	45,684,615	100.00	45,865,144	100.00

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及本公司整理

(2)市場占有率

根據國際研究機構 IC Insight 針對 109 年全球晶圓代工總產值預估達 471 億美元；統計本公司 109 全年合併營收約為新臺幣 456.8 億元，在全球晶圓代工市占率約達 2.3%。然本公司在資源整合效益下，未來市占率可望有所提升。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

根據 WSTS (全球半導體貿易統計協會)統計 109 年全球半導體，市場產值達 4,330 億美元，較 108 年的 4,123 億美元增長約 5.1%；較先前因受新冠肺炎疫情影響下修至 3.3%的成長預期為優。WSTS 預計 110 年全球半導體市場增長將加速，110 年全球半導體產值可望年增約 8.4%，主要成長動能來自於 Sensor、Logic 及 Memory 等相關產品；研調機構顧能 Gartner 也預期 110 年半導體市場將成長 11.6%以上水準。

近年由於 IDM 大廠在撙節資本支出及降低成本考量下，增加委外代工比重，有助於晶圓代工廠營收表現。根據國際研究分析機構 Omdia 預估 110 年純晶圓代工產值預期有 14 %以上的正成長，表現相對優於整體半導體產業。

自新冠肺炎疫情爆發以來，迄今已擴散全球，目前尚未能有效控制，加上中美貿易戰日益加劇，引發市場多種不確定性，或對於產品終端需求造成遞延效應，需更密切觀察其後續對全球經濟造成的影響。

(4)競爭利基

本公司 12 吋廠製程良率優異，與世界大廠同步，在先進製程上具備成本競爭力優勢，並與策略聯盟夥伴合作建立共同的設計平台和 IP，提供客製化的晶圓代工服務，包括邏輯暨特殊應用產品類、利基型動態隨機存取記憶體及 NOR / NAND 快閃記憶體等領域的晶片專業代工服務，並積極導入國際大廠與之合作，開發多樣產品。以世界級同步的製造技術及國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的優異代工服務。

(5)發展遠景之有利與不利因素與因應對策

A.有利因素

(A)市場需求穩定成長

物聯網及人工智慧的發展，創造許多由 Cloud 端到 Edge 端不同且多樣的半導體需求。在全球智慧手機發展成熟之際，提供了另外一項半導體市場長期的成長動能。於邏輯產品之技術方面，本公司充份發揮 12 吋 80nm 以上鋁製程成本優勢，在 DDIC/PWM/MCU/CIS 等特殊代工產品領域與客戶深度合作，並進一步延伸至 55nm 以下銅製程。於 8 吋則重心由 IC 擴大至分立器件，以 MOSFET/IGBT/GaN 等產品線為未來主要成長動能。8 吋及 12 吋未來目標是都要能兼顧穩定獲利及持續成長。另，於記憶體產品之技術方面，本公司及子公司除擁有完整的記憶體設計服務及製造能力外，且同時具備 DRAM/ NAND Flash 及 NOR Flash 製程平台，能夠滿足客戶多元化的記憶體產品需求。本公司及子公司將持續開發新一代記憶體製程，維持成本競爭優勢。並與代工客戶共同合作提供多樣化、高品質的記憶體產品。

(B)產品多元

本公司及子公司兼容邏輯製程及記憶體製程代工產能配置，有利於公司於景氣波動循環中進行產能彈性調配，提高產能利用率，使本公司及子公司能維持相對於代工同業較佳的穩定獲利。

(C)高客製化程度

本公司及子公司以先進技術提供 12 吋晶圓專業代工服務。不僅提供利基型記憶體先進製程以協助國內外客戶生產相關產品，為目前全球主要提供全方位記憶體產品線代工之 12 吋晶圓廠。同時，提供客製化的邏輯暨特殊應用產品代工服務，成為世界級大廠的最佳合作夥伴。

B.不利因素與因應對策

(A)同業競爭壓力增加

近年半導體產業主要支撐力道來自於行動裝置、5G、AI 等產品，各相關晶圓代工廠亦受惠，引起業界關注。而近年中國政府致力於半導體產業扶植，以打造產業鏈一條龍為目標，積極投入設備及廣納人才。在全球代工產能供給增加的情況下，可能會面臨與同業競爭壓力。

因應對策：

本公司專注於晶圓代工業務，以世界級同步的技術，搭配國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的代工服務，以共創事業高峰。至今已陸續引進不同的代工客戶，客戶的產品可應用的範圍涵蓋了 3C 應用領域－電腦、無線通訊、消費性電子及車用電子等。

同時藉由擴大與全球產官學研究機構共同進行相關製程技術開發，以期提早掌握前瞻技術，有效縮短研發時程，降低專利與技術移轉成本。本公司及子公司持續提供更優質的服務、產品及多元代工模式，以持續深化與客戶良好關係，為本公司及子公司最佳的因應之道。透過 12 吋廠與 8 吋廠整合，提供客戶更完整的產品線及更完善的服務品質。

(B)產能擴充之可能風險

因 12 吋代工客戶產能需求持續攀升，本公司近期之 12 吋產能無法滿足客戶需求。為滿足中長期營運規劃，本公司在充分評估後，已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構 12 吋生產基地。惟因需求預測會隨著市場環境變化而產生顯著的改變，當需求減少時，已添購的機器設備及增聘的人員等將造成對本公司財務表現產生負面的影響。

因應對策：

本公司會持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，若市場需求不如預期時，本公司會及時地調整其產能計劃，以降低對於公司財務表現的負面影響，且本公司相關投資計畫尚在規劃中，原則以分期、分階段，以公司財務可負擔，最小風險下擴充廠房及產能，同時兼顧公司穩健成長與滿足客戶產能需求。

本公司亦將擴廠設備風險轉嫁給客戶共同承擔，對上游 IC 設計業者來說，即使本身公司設計具有競爭力，但沒有配合製造的產能也無濟於事，因此未來五年，晶圓代工產能將成為兵家必爭之地，而客戶端爭搶產能動作更加積極。目前本公司與部分客戶間採取 Consign 的模式，由客戶購買機器設備租予本公司，再由本公司代工產出產品，客戶可確保後續晶圓取得無虞，本公司也能降低購買大量設備後需求減緩的風險。

(C)有關智慧財產權之風險

本公司係以自行研發的製程技術、營業秘密、相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，然而尚無法保證營業秘密及相關 know-how 不被竊取或仿效，若發生此情事，將導致本公司營收減少之可能性，也有可能在不知情的情況下侵害到他公司的智慧財產權，若有相關之訴訟可能導致本公司有無法製造特定產品的風險。

因應對策：

本公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益損失的可能性。包含積極主張及保護本公司所屬之智慧財產權，對於研發成功之產品基於智慧財產權，皆有申請專利保護。本公司設有智權室，以防止製程中有侵害他人智慧財產權之情事，另外對於使用到的專利，皆有取得其他公司的授權，避免有侵權的風險。

(D)氣候災害風險

半導體製造業對電力的供電量及穩定度皆有強大的要求，若發生偶發性斷電將需要重啟設備及檢查機台，因而影響產品製程進度。半導體製造業對營業用水需求量大，若有缺水的情況也將影響產能。任何氣候災害造成缺水缺電皆有影響產能的風險。

因應對策：

本公司設有不斷電系統，避免有斷電的情況，對於水資源致力回收使用，減少對水資源的損耗，並對無法於廠內再次使用之廢溶劑落實機台分流設計，於排放管路裝上選別閥進行切換排放管路，有效減少廢溶劑之排放量，且將其餘廢水排入廢水場或回收系統，進行水回收使用，使得本公司 109 年度 8A 廠製程用水回收率達 85%以上。

本公司與政府部門有良好的溝通渠道，氣候災害風險管控皆有充分討論因應對策，並已密切監控水情狀況，於水源吃緊時備妥水車，一旦有需要便可啟動至與政府協商的地區載水應急。

(E)匯率風險

本公司營收不論內外銷，皆採外幣計價，交易幣別採美元交易，惟本公司資本支出及進貨付款幣別主要有美元、日幣及台幣，無法互抵之美元應收款項在轉換成新臺幣時，仍會因持有美元淨資產部位而產生匯兌損益，故在美元持續有貶值趨勢之情況下，兌換損失可能將侵蝕公司之獲利。本公司視匯率市場變動、實際部位和資金狀況，採自然避險及配合遠期外匯合約以規避匯率風險。

因應對策：

本公司因應匯率變動之管理採取穩健策略，主要係採自然避險的政策；另財務單位密切留意國際金融狀況，掌握最新之匯率市場變動，並請往來銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率走勢，並視實際外幣部位和資金狀況，配合遠期外匯合約以規避匯率風險。

2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)代工生產主要產品之重要用途

①邏輯暨特殊應用產品晶圓代工之主要產品，其重要用途說明如下：

顯示驅動 IC(Display Driver IC)主要用於大中小尺寸面板及電子紙之螢幕驅動，可用於電視、顯示器、智慧型手機、平板電腦、電子書、電子標籤等產品。

本公司代工生產之電源管理 IC、分離式元件，主要應用於各種電腦及其週邊產品、手持行動裝置、通訊應用產品、消費性電子及車用電子產品等。

影像感測 IC 產品主要用於安防、手機、電腦攝像頭等之 COMS 影像感測器。

記憶體整合晶片應用於微控制器、白色家電、搖控器、智慧卡產品。

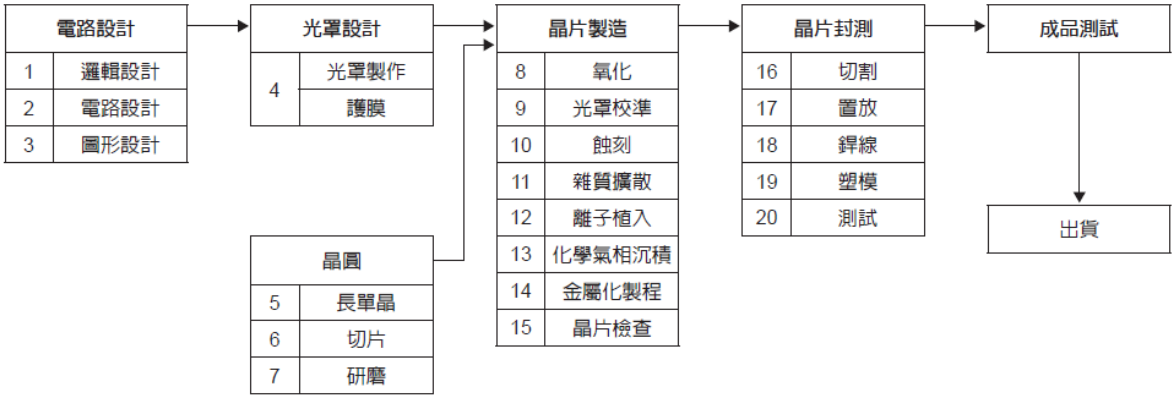
②記憶體晶圓代工之主要產品，其重要用途說明如下：

DRAM 產品的應用範圍則主要為電腦、通訊及消費性電子或車用電子等產品，如：個人電腦、筆記型電腦、印表機、行動電話、數位相機、數位電視及無線網路產品等。

NOR/NAND Flash 則是以手持行動裝置、消費性電子產品及工業用電子產品，或是智能家電及智慧電錶等相關應用。

(2)主要產品之產製過程

本公司的主要晶圓代工產品，是邏輯暨特殊應用及記憶體產品。其晶圓製造過程極為精密與繁複，要在無塵潔淨的晶圓製造環境中生產，經過黃光、擴散、薄膜、蝕刻等數百道製程，往復回流製造，晶圓產出後，再經過電路針測、封裝與最後測試，才能完成最終的成品。



3.主要原料之供應狀況

本公司之主要原料係為矽晶圓、光阻、氣體及化學品等。本公司之主要供應商皆屬長期配合之廠商，且雙方均維持良好穩定的合作關係；本公司為分散供貨集中問題，盡可能維持二家以上之供貨來源，以確保供貨穩定性。

4.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

(1)最近二年度毛利率變動情形

單位：新台幣仟元：%

項目 \ 年度		108 年度	109 年度
		金額	金額
營業收入	邏輯暨特殊應用產品	16,703,015	25,657,228
	記憶體產品(片)	10,809,807	14,049,468
	記憶體產品(顆)	8,384,299	5,977,919
營業毛利	邏輯暨特殊應用產品	3,314,103	7,678,612
	記憶體產品(片)	2,154,296	3,175,636
	記憶體產品(顆)	(2,467,731)	138,163
毛利率	邏輯暨特殊應用產品	19.84%	29.93%
	記憶體產品(片)	19.93%	22.60%
	記憶體產品(顆)	(29.43%)	2.31%
毛利率變動率	邏輯暨特殊應用產品	(26.13%)	50.83%
	記憶體產品(片)	(42.53%)	13.42%
	記憶體產品(顆)	(192.47%)	(107.85%)

(2)毛利率變動說明

109 年度因全球半導體貿易需求增加，銷售單價及產能利用率上升，致毛利率增加。

5.主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例

單位：新臺幣仟元

項目	108 年度				109 年度				110 年第三季			
	供應商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	供應商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	供應商名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	2,025,643	12.68	無	A 公司	1,588,215	9.04	無	A 公司	1,125,199	9.00	無
	其他	13,953,979	87.32		其他	15,972,459	90.96		其他	11,380,838	91.00	
	合計	15,979,622	100.00		合計	17,560,674	100.00		合計	12,506,037	100.00	

變動說明：本公司及子公司對 A 公司進貨金額減少，主係因原料採購價格下降，加上本公司及子公司積極分散供貨來源所致。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例

單位：新臺幣仟元

項目	108 年度				109 年度				110 年第三季			
	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲客戶	6,467,776	18.02	無	乙客戶	7,721,858	16.90	無	乙客戶	5,130,749	11.19	無
2	乙客戶	5,180,476	14.43	無	甲客戶	2,530,010	5.54	無	甲客戶	2,523,011	5.50	無
	其他	24,248,869	67.55		其他	35,432,747	77.56		其他	38,211,384	83.31	
	合計	35,897,121	100.00		合計	45,684,615	100.00		合計	45,865,144	100.00	

變動說明：前二大銷貨客戶銷售金額之變動，主係受市場終端需求及價格波動所致。

6.最近二年度生產量值單位：

仟片；仟顆；新臺幣仟元

生產量值 年度 / 主要商品	108 年度			109 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
邏輯 （仟片）	1,690	672	11,624,214	1,740	1,055	17,605,237
記憶體（仟片）		304	7,505,158		419	10,662,573
記憶體（仟顆）		309,909	9,511,712		225,336	5,946,056
合計	1,690	-	28,641,084	1,740	-	34,213,866

註：產能/產量係 12 吋晶圓約當片數。

變動分析：

(1)邏輯產品，主係受惠於需求增加，新增 12 吋廠產能，故產量隨之增加所致。

(2)記憶體產品，主係因 108 年度全球貿易形勢動盪、記憶體市場萎縮，導致代工訂單疲軟，故產值下滑所致。

7.最近二年度銷售量值

單位：仟片；仟顆；新臺幣仟元

銷售量值 年度 / 主要商品	108 年度				109 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
邏輯 （仟片）	496	12,038,551	168	4,664,464	774	18,662,546	275	6,994,682
記憶體（仟片）	276	9,665,665	30	1,144,142	364	11,988,907	59	2,060,561
記憶體（仟顆）	58,249	1,776,699	249,440	6,607,600	80,845	2,286,815	136,501	3,691,104
合計	-	23,480,915	-	12,416,206	-	32,938,268	-	12,746,347

註：銷售量係 12 吋晶圓約當片數。

變動分析：

(1)邏輯產品，主係受惠於新冠肺炎疫情帶動居家上班與遠距教學等消費行為，筆記型電腦/平板電腦需求增加，加上 5G 快速發展、多鏡頭手機、4K/8K 電視的滲透率上升，使得包含顯示驅動、電源管理、影像感測等邏輯產品 IC 銷售成長，致 109 年度邏輯產品銷值相較 108 年度成長。

(2)記憶體產品，主係因新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長，致記憶體市況雖至谷底回溫，惟成長力道相對持平，且本公司為降低記憶體價格波動之營運風險，於 108 年度起進行調整產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，綜上因素，使得 109 年度記憶體產品銷值相對較 108 年度僅微幅成長。

(三)最近二年度及截至公開說明書刊印日止

1.最近二年度從業員工人數、年歲、年資及學歷分布

單位：人；%

項目＼年度		108 年度	109 年度	110 年截至 09 月 30 日止
員工人數	直接人員	1,850	1,898	1,939
	間接人員	5,028	5,276	5,367
	合計	6,878	7,174	7,306
平均年歲(歲)		37.77	38.07	38.59
平均服務年資(年)		9.62	9.88	10.2
學歷分布比率(%)	博士	0.65	0.68	0.67
	碩士	30.50	31.77	32.11
	大專	53.85	53.05	54.07
	高中	14.93	14.40	14.03
	高中以下	0.07	0.10	0.12

2.經理人、技術及研究發展人員暨其他員工之流動情形

單位：人；年；%

年度		108 年度	109 年度	110 年截至 09 月 30 日止
上期員工人數		6,931	6,878	7,174
本期新進人數		545	964	697
離職人數	經理人	1	0	2
	研發人員	60	70	63
	一般職員	473	574	479
	合計	534	644	544
資遣及退休人數		64	24	21
期末員工總人數		6,878	7,174	7,306
離職率(註)		8.00	8.52	7.18

註：離職率=離職人員(含資遣及退休)/(期末人數+離職人員(含資遣及退休))。

(四)環保支出資訊

1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明

(1)申領污染設施設置許可證或污染排放許可證

類別\廠區	8A(含 8AD)	8B	P1/2	P3
固定污染源操作許可證	V	V	V	V
水污染防治措施計畫	V	V	V	V
毒性化學物質登記文件/核可文件	V	V	V	V
廢棄物清理計劃書	V	V	V	V
廢水排放納管許可	V	V	V	V

- 各廠皆依法令要求完成污染設施之排放許可證申請。
- P1/2 及 P3 廠區已於 108 年 5 月銜接原力晶科技廠設施，取得各類許可證。

(2)最近兩年度繳納繳納污染防治費用

單位：新臺幣仟元

類別\年度	108 年度	109 年度
空氣污染防制費	320.70	459.57
廢水納管費用	63,728.27	73,190.93
廢棄物處理費用	106,004.27	134,946.73

(3)設立環保專責單位人員

類別\廠區	8A(含 8AD)	8B	P1/2	P3
空氣污染防制專責人員	V	V	V	V
水污染防治專責人員/專責單位	V	V	V	V
廢棄物專業技術人員	V	V	V	V
毒性化學物質專業技術管理人員	V	V	V	V
● 各廠皆依法令要求完成專責人員及代理人之設置。 ● P1/2 廠因廢水許可核准量≧五仟立方公尺，故設置為水污染防治專責單位。				

2.列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益

110 年 09 月 30 日；單位：套或台；新臺幣仟元

設備名稱	取得日期	數量	投資成本	未折減餘額	用途及預計可能產生效益
廢水處理設備	85.10~110.04	193	2,709,357	688,757	1.處理製程產出之廢水至符合園區納管標準(如:氨氮/氟系/酸鹼系/CMP 等廢水)。 2.處理民生排放之廢污水(化糞池/餐廚)至符合園區納管標準。
廢氣處理設備	85.09~110.09	1,261	4,231,623	816,780	1.處理製程產生之酸性/氨性/有機氣體。 2.處理製程使用之溫室氣體，降低碳排放量。
廢棄物處理設備	86.07~110.09	41	288,846	29,877	建置廢液收集系統及自廠再利用設施，降低清除處理相關風險。
噪音處理設備	85.10~109.01	6	26,957	4,250	降低發電機等設施造成之噪音，以符合各時段之週界噪音標準。
毒化物監測設備	86.03~110.06	99	243,622	34,060	建置偵測警報／洩漏防護設施／緊急應變處理設備，降低洩漏造成之人員傷害或環境污染之風險

3.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過

保護環境、綠色生產及善盡企業社會責任為公司經營管理重要的一環，本公司於 97 年通過環境管理系統 ISO14001 驗證，除系統運作定期稽核查驗外，每三年均重新通過外部機構的重新驗證，且在 106 年 8 月順利通過了 ISO14001:2015 改版驗證，後續因應組織調整及整併需求，於 107 年 12 月改名為力晶積成電子製造股份有限公司，並於 108 年 5 月收購母公司力晶科技(股)公司之相關營業及淨資產，109 年 8 月亦順利通過 ISO14001:2015 三年重新驗證，各廠區證書之有效性從未間斷，且最近二年度及截至公開說明書刊印日止並無污染糾紛事件。

4.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應

對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)

由於本公司一向恪遵環保法令，以持續降低污染排放為廠內環保工作的目標，最近二年度截至公開說明書刊印日止未曾因環境污染事件遭受相關單位之處分而有所損失，最近二年度及截至公開說明書刊印日止並未發生任何污染糾紛事件。

5.說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出

本公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止未曾發生環保檢測不合標準而受罰鍰之情事。

(五)勞資關係

1.列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1)員工福利措施

①勞工保險及全民健康保險：本公司員工均參加勞工保險及全民健康保險。

②團體保險：除了員工本人受惠外，亦嘉惠員工之配偶與子女，使同仁與家庭皆能受到保障。

③員工保健計劃：新進員工體格檢查及員工每年健康檢查。

④餐廳：公司設有餐廳，提供自助餐、快餐及麵食等各式餐點，午餐、晚餐及宵夜皆由公司補助，同仁僅需支付少許餐費即能享有豐盛之餐點。

⑤員工宿舍：為使遠道技術員就近解決住的問題，公司備有直接人員宿舍，並提供水電、冷氣套房之舒適生活環境。

⑥交通車：提供新竹、竹東、竹北、湖口、頭份、苗栗等線交通車，配合上、下班時間，供直接員工免費搭乘。

⑦獎金制度：公司依營運狀況發放激勵獎金。

⑧福利活動：職工福利委員會不定期舉辦社團活動、國內旅遊、卡拉 OK 比賽、年終晚會活動，充分聯絡員工之間的情感，促進員工對組織的向心力，提昇工作士氣。

⑨社團活動：為鼓勵員工從事正當休閒活動，由員工自行組成各類社團，職工福利委員會給予經費補助。

(2)進修及教育訓練

公司備有完善教育訓練規畫，讓員工能在適才適所工作環境中，發揮自我潛能、提昇工作績效，達到企業發展與自我成長雙贏目標。公司並辦理多元化及各項專長訓練，給予員工完整的專業技能養成及職涯發展機會。

(3)退休制度與其實施情形

公司勞工退休辦法悉依勞動基準法訂定，勞退舊制員工由公司每月提撥「勞工退休準備金」交由勞工退休準備金監督委員會，以該委員會名義存入台灣銀行專戶。並由「勞工退休準備金監督委員會」負責管理監督及審核退休準備金相關事宜。自 94 年 7 月 1 日起依「勞工退休金條例」以每月工資 6%按月為選擇新制員工及新進員工提繳勞工退休金。

(4)勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施

公司重視員工意見，提供多種管道以促進勞資雙方之溝通協調，如設置員工意見箱及網路溝通平台等，深入瞭解員工對管理與福利制度意見及想法，以持續良好勞資關係。

2.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

(六)有無因應景氣變動之能力

本公司兼容邏輯製程及記憶體製程代工產能配置，有利於公司於景氣波動循環中進行產能彈性調配，提高產能利用率，使本公司能維持相對於代工同業較佳的穩定獲利。

(七)發行公司及其子公司(包括母子公司間交易事項)之關係人間交易事項是否合理

本公司及子公司與關係人間之交易並無非常規交易之情事，其交易事項請參閱經會計師查核簽證之財務報告附註說明。

二、不動產、廠房及設備、其他不動產或其使用權資產

(一)自有資產

1.取得成本達實收資本額百分之二十或三億元以上之不動產、廠房及設備名稱、數量、取得日期、取得成本、重估增值及未折減餘額，並揭露其使用及保險情形、設定擔保及權利受限制之其他情事

110 年 09 月 30 日；單位：新臺幣仟元

不動產、廠房及設備名稱	單位	數量	取得年月	原始成本	重估增值	未折減餘額	利用狀況			保險情形	設定擔保及權利受限制之其他情事
							本公司使用部門	出租	閒置		
房屋及建築物	棟	2	85/10	2,225,064	-	-	廠務部	無	無	已投保	無
房屋及建築物	棟	8	91/06~107/11	7,510,431	-	3,504,456	廠務部	無	無	已投保	已抵押
房屋及建築物(興建中)	棟	3	110/03~110/09	783,382	-	783,382	-	-	-	已投保	無
半導體設備	台	23	93/08~109/11	12,020,535	-	1,482,639	黃光工程部	無	無	已投保	無
半導體設備	台	5	103/12~108/08	6,891,141	-	4,356,360	黃光工程部	無	無	已投保	已抵押
半導體設備	台	1	106/09	483,867	-	382,001	良率工程部	無	無	已投保	已抵押
半導體設備	台	4	92/06~96/09	2,754,962	-	9,326	自動化工程部	無	無	已投保	無
半導體設備	台	1	109/04	362,759	-	333,392	自動化工程部	無	無	已投保	已抵押
半導體設備	套	3	85/10~94/07	2,685,900	-	4,720	廠務部	無	無	已投保	無
半導體設備	套	12	91/11~107/12	8,162,307	-	871,883	廠務部	無	無	已投保	已抵押

2.閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上之不動產名稱、面積、座落地點、取得日期、取得成本、重估增值、未折減餘額、公告現值或房屋評定價值、公允價值及預計未來處分或開發計畫：無。

(二)使用權資產

金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上之使用權資產租賃標的名稱、數量、租賃期間、出租人名稱、原始帳面金額、未折減餘額，並揭露其保險情形及租約之重要約定事項。

110 年 09 月 30 日；單位：新臺幣仟元

租賃標的名稱	單位	數量	租賃期間	出租人	原始帳面金額	未折減餘額	保險情形	租約之其他重要約定事項
園區土地租金-P1/2	筆	1	108/01~126/12 (註 1)	新竹科學工業園區管理局	628,797	554,952	無	無
園區土地租金-P3	筆	1	95/12~114/12 (註 1)	新竹科學工業園區管理局	395,289	339,544	無	無
園區土地租金-8A	筆	1	106/09~125/12 (註 1)	新竹科學工業園區管理局	460,972	406,837	無	無
園區土地租金-P5	筆	1	109.07~128.12 (註 1)	新竹科學工業園區管理局	651,431	631,074	無	無
半導體設備	台	63	108/10~120/09	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1,382,321	1,105,857	已投保	無
半導體設備	台	37	109/04~120/09	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1,256,617	1,068,125	已投保	無
半導體設備	台	1	110/03~114/12	聯發科技股份有限公司	362,390	353,098	已投保	(註 2)
半導體設備	台	1	110/05~114/12	聯發科技股份有限公司	346,670	344,448	已投保	(註 2)
半導體設備	台	1	110/09~113/06	群創光電股份有限公司	355,303	355,303	已投保	(註 2)

註 1：因預計租約到期後將續租，在計算使用權資產之原始帳面價值時，所採用之年限係按廠房之折舊到期日計算；P1/2 與 8A 之折舊到期日分別為 131 年 05 月，P3 為 127 年 06 月，P5 為 149 年 06 月。

註 2：以融資租賃方式承租，租賃期間屆滿時，該機器設備所有權自動移轉為本公司所有。

(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率

1.生產工廠現況

110 年 09 月 30 日；單位：平方公尺；人

項目 / 工廠	建物面積	員工人數	生產商品種類	目前使用狀況
8A(含 8AD)	83,758	7,306	Driver, MCU, PMIC, Discrete	正常使用
8B	63,743		Discrete	正常使用
P1/2	261,791		Driver, CIS, MCU, PMIC, DRAM, Flash	正常使用
P3	131,913		DRAM	正常使用

2.最近二年度設備產能利用率

單位：仟片；仟顆；新臺幣仟元；%

生產量值 / 年度 / 主要商品	108 年度				109 年度			
	產能	產量	產能利用率	產值	產能	產量	產能利用率	產值
邏輯（仟片）	1,690	672	84.33	11,624,214	1,740	1,055	100.00	17,605,237
記憶體（仟片）		304		7,505,158		419		10,662,573
記憶體（仟顆）		309,909		9,511,712		225,336		5,946,056
合計	1,690	-		28,641,084	1,740	-		34,213,866

註：產能/產量係 12 吋晶圓約當片數。

三、轉投資事業

(一)轉投資事業概況

110 年 09 月 30 日；單位：新臺幣仟元；仟股；%

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價(註)	會計處理方法	最近年度(109年度)投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例				投資損益	分配股利	
Global Powertec Co., Ltd	從事各式投資業務	1	(57,520)	-	100.00	(57,520)	-	權益法	(20,719)	-	-
PowerMemory Inc.	從事半導體及電子產品開發、製造、銷售及輸出入	703,165	19,548	500	100.00	19,548	-	權益法	(1,802)	-	-
Maxram Inc.	從事半導體及電子產品開發、製造、銷售及輸出入	22,415	21,236	800	100.00	21,236	-	權益法	2,127	-	-

資料來源：109 年度及 110 年第二季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

註：非上市櫃公司，故無市價資訊。

(二)綜合持股比例

110 年 09 月 30 日；單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Global Powertec Co., Ltd	-	100.00	-	-	-	100.00
PowerMemory Inc.	500	100.00	-	-	500	100.00
Maxram Inc.	800	100.00	-	-	800	100.00

(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：無。

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱、及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數：無。

四、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術合作契約	日商 Micron Japan 公司	92.08~110.07	技術移轉與授權	無
聯貸合約	臺灣土地銀行(主辦銀行)及其他聯貸銀行等7家金融機構	107.01~114.01	中長期借款	財務比率需符合合約所訂標準
聯貸合約	臺灣土地銀行(主辦銀行)及其他聯貸銀行等6 家金融機構	108.02~113.02	中長期借款	財務比率需符合合約所訂標準
聯貸合約	彰化商業銀行股份有限公司(主辦銀行)及其他聯貸銀行等14家金融機構	109.11~116.01	中長期借款	財務比率需符合合約所訂標準
園區土地租金-P1/2 廠	科技部新竹科學園區管理局	108.05.24~127.12.31	承租土地	無
園區土地租金-P3 廠	科技部新竹科學園區管理局	108.05.24~127.12.31	承租土地	無
8A 廠科管局土地	科技部新竹科學園區管理局	104.04.01~123.12.31	承租土地	無
8B 廠科管局土地	科技部新竹科學園區管理局	106.09.15~125.12.31	承租土地	無
園區土地租金-P5 廠	科技部新竹科學園區管理局	109.07.01~128.12.31	承租土地	無
嘉晶 8AD 廠	嘉晶電子股份有限公司	103.12.01~115.11.30	承租土地	無
銅鑼園區土地	科技部新竹科學園區管理局	109.07~128.12	承租土地	無

五、以科技事業申請股票上市者，應增列事項

(一)產品技術分析暨持續發展之研究計畫

1.就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升

(1)產品生產開發技術之層次及來源

本公司及子公司長期耕耘於半導體晶圓代工服務，透過 Open Foundry 營運模式，從晶片設計到製造服務，可根據不同的屬性和需求，提供客戶所需之代工服務，藉此與客戶建立緊密及彈性的合作機制。藉由活化成熟生產技術並善用製程優勢，本公司及子公司得以提供大規模高性價比之產品技術。所提供的製程技術及製造解決方案，包括邏輯暨特殊應用以及記憶體兩大群組產品之代工技術：

A.邏輯暨特殊應用產品之代工技術

摩爾定律在 28 奈米節點之後，提升幅度減緩顯示先進邏輯製程不是市場唯一方向，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊應用製程(應用於顯示驅動 IC、分離式元件、電源管理晶片、CMOS 影像感測器、嵌入式非揮發性記憶體之製造)及多元代工合作模式，以有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是本公司及子公司的競爭策略，28 奈米以上成熟製程市場依然有相當大的規模，包括 IoT、工業、汽車電子等應用。隨著智慧型手機產品的普遍及人工智慧相關產品的推出，促使物聯網(IoT)產業鏈逐漸成形，更帶動上下游

相關元件需求。在消費性終端產品「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，對專業晶圓代工廠而言，能提供客戶客製化製程開發更形重要。

(A)高壓製程(High Voltage)

應用於手機、筆記型電腦、平板、TV 及電腦螢幕等電子產品的面板顯示驅動 IC。由於新冠肺炎疫情的關係居家上班與遠距教學成為新常態，筆記型電腦/平板電腦需求增加，加上 4K/8K 電視的滲透率上升，造成驅動 IC 需求增加、缺貨、價格上漲。本公司及子公司將 8 吋大面板驅動 IC 高壓製程移植到 12 吋廠生產，故能以 12 吋晶圓廠生產大面板驅動 IC 之晶圓代工廠，晶粒生產成本相較於同齡 8 吋晶圓廠可大幅降低 30%。

(B)分離式元件(Discrete)

應用在各類產品如手機/平板電池保護、PC/NB 主機板、工具機、USB、訊號開關、馬達驅動及 LED lighting 等。5G 商轉全球正式邁入 5G 世代，相較於 4G、5G 基站的 MOSFET 需求成長大於 4 倍，本公司及子公司除 8 吋擴廠外、亦開始著手 12 吋廠開始分離式元件平台，目前亦為台灣主要在 12 吋晶圓廠建立此產品線之晶圓代工廠。

(C)CMOS 影像感測器

目前以 CIS 製程為客戶生產高解析度之影像感測晶片，並自行開發後段彩色濾光膜(color filter)與微鏡頭(micro lens)製程，以提供客戶更全面的 CIS 代工服務。智慧型手機鏡頭微 CMOS 影像感測器最大需求來源，手機使用鏡頭逐年增加目前已經來到平均單隻手機有四顆鏡頭；加上各國安防監控影像感測器需求亦持續上升，特別是在大陸地區。本公司及子公司與國際大廠合作，在手機輔助鏡頭、安全監控器及車用行車紀錄器、倒車輔助等應用的晶片代工市占率遠遠高於其他晶圓代工競爭者。

(D)電源管理製程(Power Management)

應用在各類 Power IC，如手機 PMIC、Charger、LDO、Boost converter、LED lighting、AD/DC、HV motor driver。108~110 年各國開始全力支援 5G 商轉，5G 技術以高速傳輸、低延遲、大量連網為特色。除了 5G 基礎建設帶動的商機，也將引發終端設備新一波的升級換機需求。相對 4G 手機，5G 手機 PMIC 使用顆數是 4~5 倍，晶片用量則是 2.5~3 倍。本公司及子公司與世界大廠合作，率先在 12 吋生產手機用 PMIC 晶片，並與客戶共同開發下一代電源管理製程。

(E)嵌入式非揮發性記憶體(Embedded NVM)

應用消費性電子、工程及車用電子等。因人工智慧技術及效能的提升，物聯網及 5G 行動通訊建設臻於完善，興起許多新型態終端產品，使晶片設計複雜度不斷提昇；除追求晶片功能整合及低功耗外，還需考慮生產效能或是進一步要求半導體製程技術微縮。目前除了提供 110nm~55nm 製程平台且進入量產之外，亦積極開發 40nm 製程平台，提供客戶更低功耗、更小單位元件面積之產品。

B.記憶體產品之代工技術

(A)動態隨機存取記憶體(DRAM)

本公司及子公司在 DRAM 代工領域深耕多年，為目前業界少數可提供 12 吋先進 DRAM 製程的代工廠商。目前除了 45nm 等成熟製程外，更積極協助客戶導入 38nm 及 25nm 製程，以滿足產品多樣化的需求。

(B)快閃記憶體(NAND/NOR Flash)

本公司及子公司多年累積快閃記憶體產品技術成果，在 NAND Flash 方面目前已提供 40nm 及 28nm 代工製程與產品設計服務。而 24nm 製程也已進入試產階段。

NOR Flash 方面，目前已提供客戶 90nm 製程 NOR Flash 代工，48nm 製程已於 109 年進入試產階段，並於 110 年進入量產將更具成本優勢。

(2)產品生產開發技術之確保與提升

本公司及子公司係以自行研發的製程技術、營業秘密、相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，為保護公司研發成果及技術之智慧財產權，各階段之研發文件及資料皆上傳至有授權管制之文件管理系統中，並且將新產品相關製程之研發成果申請專利權保護。本公司及子公司除透過內部課程自行培育研發人才外，亦透過與共同開發夥伴密切合作、與工研院及學校合作，確保產品技術持續提升。

2.現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究發展計劃

(1)現在主要產品之競爭優勢

本公司及子公司之代工技術分為邏輯暨特殊應用以及記憶體兩大群組產品，以下就主要產品分析其競爭優勢：

(A)邏輯暨特殊應用產品晶圓代工業務

一般 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，本公司及子公司能提供低成本的 12 吋鋁製程平台，相較同樣產品製程技術的 8 吋鋁製程，本公司及子公司 12 吋鋁製程所產出之最後產品晶片成本可降低 30%以上，大幅提升客戶產品競爭力。

本公司及子公司著重在 IoT、工業、汽車電子等特殊應用產品市場，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊製程及多元代工合作模式，有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是本公司及子公司的競爭策略。

a.高壓製程(High Voltage)

本公司及子公司提供低成本的 12 吋鋁製程 150nm~80nm 高壓製程平台用於大小面板驅動 IC 產品，有別於一般 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，相較同業產品製程技術的 8 吋鋁製程，本公司及子公司晶粒成本可大幅降低 30%以上。此外，小面板驅動 IC 需要內建靜態隨機存取記憶體(SRAM)，記憶體之單位元件大小會影響到產品晶片大小與成本，本公司及子公司提供之 55nm~40nm 高壓製程平台之 SRAM 記憶體之單位元件與競爭對手對比相當的競爭力。

b.分離式元件(Discrete)

本公司及子公司著手於 12 吋廠開發分離式元件平台，亦為目前台灣主要在 12 吋晶圓廠建立此產品線之晶圓代工廠，相較同樣產品製程技

術的 6 吋及 8 吋製程，本公司及子公司所產出之最後產品晶片成本可降低 30%以上。

c.CMOS 影像感測器

本公司及子公司 CIS 影像感測器平台，提供低成本、低耗電、高穩定性及整合性高等優勢，平均良率高於 97%。

d.電源管理製程(Power Management)

本公司及子公司憑藉技術優勢，積極開發拓展各節點類比電源管理晶片平台以符合市場與客戶需求。數位電路面積降為競爭對手 1/4，類比電路面積降為競爭對手 9/10。

e.嵌入式非揮發性記憶體製程(Embedded NVM)

本公司及子公司 eFlash 採用新一代 Flash 架構，需要額外光罩層數與最大電壓，均優於競爭對手。

(B)記憶體晶圓代工業務

a.動態隨機存取記憶體(DRAM)

本公司及子公司 DRAM 記憶體代工產品線有別於其他 IDM 廠，為目前全球主要能提供客製化 DRAM 產品及完整優化製程服務的公司，為記憶體 IC 設計公司缺一不可的重要合作夥伴。

b.快閃記憶體(NAND/NOR Flash)

本公司及子公司多年累積快閃記憶體產品技術成果，在 NAND Flash 方面，提供 40nm 及 28nm 代工製程與產品設計服務。鎖定行動通訊應用裝置、消費性電子產品、汽車聯網、及工業應用市場，提供低功率節能及高可靠度的 NAND Flash 產品。在 NOR Flash 方面，本公司及子公司 12 吋晶圓廠機台配置用於生產 NOR Flash 及具成本優勢。

(2)現在主要產品之生命週期及持續發展性

半導體晶片終端應用產品非常廣泛，惟隨著各項電子終端產品要求「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，終端產品生命週期縮短也影響著半導體製造晶圓生命週期持續縮短，半導體製程技術密集度也越來越高，本公司及子公司除強化自身產品技術線外，持續往下一代先進製程進行開發，同時也加強既有之成熟製程能力。受惠於車用、5G、人工智慧物聯網(AIoT)等終端應用快速興起，晶圓代工需求強勁，對全球半導體產業造成結構性的改變，目前市場對成熟製程的晶片需求出現大爆發的情況，未來供不應求將更嚴重。

(3)新產品之研究發展計劃

本公司及子公司為因應 5G 基地台、車用元件及物聯網市場，制定多項研發計畫，透過過往經驗與生產製造能力，預計研發多項邏輯暨特殊應用產品代工及記憶產品代工技術，並以本公司及子公司原有核心技術為基礎，逐步推進先進製程以發展至各種產品之應用技術，每年約投入營業收入之 7%作為研究開發經費。茲將目前研發項目及預訂時程列示如下：

研發項目	說明
55nm L55 新應用和新客戶導入	預定 2022 量產
40nm HV40 高壓製程	預定 2021 完成開發

研發項目	說明
40nm L40 邏輯製程客戶導入	預定 2022 量產
40nm eFlash (IMC40)製程	預定 2023 完成開發
38nm DRAM 55nm Logic wafer stacking 製程	預定 2021 完成開發
WOW Logic and DRAM stacking (3D Interchip)製程	預定 2022 完成開發
90nm CIS 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_BSI 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_Global Shutter 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_Bio-Chop 製程	預定 2022 完成開發
21nm DRAM 8GD4 (186AD)製程	預定 2021 完成開發
25nm DRAM 4G DDR3 RDL(KGD)製程	預定 2021 完成開發
38nm DRAM embedded capacito 製程	預定 2022 完成開發
24nm NAND Flash (DK24)製程	預定 2022 完成開發
80nm BCD 1.2V(1.8V)/5V 製程	G1:5V GOX 2022 開發完成 G2:1.8V GOX 2023 開發完成
90nm BCD(SG90)	預定 2021 完成開發
130nm BCD 1.5V/5V/80V	預定 2022 完成開發
GaN on Si Power Device	預定 2023 完成開發
150nm Micro-bolometer IR Image Sensor	預定 2022 完成開發
110nm MCU	預定 2021 完成開發
110nm Data storage	預定 2021 完成開發
Discrete, MLSC LD and HD capacitor	預定 2021 完成開發

(二)如其事業係屬生物技術工業、製藥工業或醫療儀器工業者，應增列其依法令取得主管機關許可進行人體臨床試驗或田間實驗者或在國從事生物技術工業或醫療儀器工業研究發展，且已有生物技術或醫療儀器相關產品製造及銷售或提供技術服務之實績暨最近一年度產品及相關技術服務之營業額，研究發展費用所占本公司總營業額之比例情形：不適用。

(三)公司如於提出上市申請前一年度因調整事業經營，終止其部分事業，或已將其部分之事業獨立另設公司、移轉他公司或與他公司合併者，應分別予以記載說明其終止、移出或合併之事業暨目前存續之營業項目，並提出目前存續營業項目前一年度之營業額、研究發展費用占公司該年度總營業額之比例情形：無此情事。

參、發行計畫及執行情形

一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載事項

(一)108 年度公開發行前辦理第一次發行新股作為受讓力晶科技相關 12 吋晶圓廠及相關營業、淨資產案之對價

1.計畫內容

(1)力晶科技(股)公司為有效整合集團資源，進行組織重組提高整體競爭力，故將全部或主要部分之相關營業及淨資產受讓予本公司，由本公司自收購讓與基準日起承受力晶科技(股)公司之相關營業及淨資產，並由本公司發行新股予力晶科技(股)公司作為對價。

(2)目的事業主管機關核准日期及文號:108 年 05 月 13 日竹商字第 1080012910 號函核准。

(3)計畫所需資金總額：新臺幣 22,608,182 仟元。

(4)資金來源

增資發行新股 2,260,818 仟股，每股面額 10 元，總計增加實收股本 22,608,182 仟元，以每股普通股面額 10 元原價發行換取力晶科技(股)公司所讓與營業與淨資產之帳面價值。

(5)計畫項目及資金運用情形

本公司此次發行新股作為受讓力晶科技(股)公司之相關營業及淨資產之對價。

(6)本次計畫輸入證期局指定申報網站日期：不適用。

2.執行情形及效益分析

(1)執行情形

本公司業於 108 年 05 月 01 日收購讓與基準日完成受讓並發行新股相關事項，並於 108 年 05 月 13 日完成辦理變更登記。

(2)執行效益分析

本公司於本次受讓發行新股之執行效益顯現於 107 年度及 108 年上半年度之兩期間財務數字差異結果，請詳下表

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度		107 年度	108 年上半年度
基本財務資料	流動資產	3,601,769	19,027,326
	不動產、廠房及設備	7,544,622	46,272,607
	總資產	11,918,488	69,698,850
	流動負債	3,952,307	17,101,445
	負債總額	7,021,049	42,928,243
	營業收入	7,637,449	16,757,678
	利息支出	729	221,306
	每股盈餘(元)	2.22	(0.63)
財務結構	負債占資產比率	58.91%	61.59%

項目 \ 年度		107 年度	108 年上半年度
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	105.59%	113.67%

註：各期為經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；其中 107 年度係為未追溯重編之財務資料，108 年第二季合併財務報告之相關數字皆為經會計師查核簽證或核閱。

本公司於 108 年 05 月方才完成受讓母公司力晶科技(股)公司相關營業及淨資產，經由本次組織重組，有效整合集團資源進而提升生產動能，以降低未來營運受全球總體經濟因素變遷之不確定性。在營運成果方面，本公司 108 年上半年度營業收入已達 16,757,678 仟元，每股盈餘方面 108 年上半年度為(0.63)元，較 107 年度為低，主係因受讓母公司之相關營業及淨資產，方於 108 年 05 月才完成所致，經由此次受讓並進行增資發行新股使本公司得以專心致力於代工事業發展，進一步提升營運績效，故本公司本次受讓母公司淨資產發行新股之計畫執行效益已顯現。

(二)108 年度公開發行前辦理第二次現金增資案

1.計畫內容

(1)目的事業主管機關核准日期及文號：108 年 10 月 01 日竹商字第 1080028229 號函核准。

(2)本次計畫所需資金總額：新臺幣 4,040,000 仟元。

(3)資金來源

於 108 年 09 月 06 日辦理現金增資發行普通股 400,000 仟股，每股發行價格為新臺幣 10.1 元，募集總金額為新臺幣 4,040,000 仟元。

(4)資金運用計畫及資金運用進度

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所須資金實際總額	實際或預定資金運用情形	
			108 年第四季	109 年第一季
充實營運資金	109 年第一季	4,040,000	2,020,000	2,020,000

(5)本次計畫輸入證期局指定申報網站日期：不適用。

2.執形情形及效益分析

(1)執行情形

單位：新臺幣仟元

計畫項目	執行狀況		108 年第四季	109 年第一季	進度超前或落後情形、原因及改進計畫
充實營運資金	支用金額	預定	2,020,000	2,020,000	-
		實際	2,020,000	2,020,000	
	執行進度	預定	50%	100%	
		實際	50%	100%	

(2)執行效益分析

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度		108 年第二季(增資前)	108 年第二季(增資後)
基本財務資料	流動資產	19,027,326	23,067,326
	流動負債	17,101,445	17,101,445
	資產總額	69,698,850	73,738,850
	負債總額	42,928,243	42,928,243
	利息支出	221,306	221,306
	營業收入	16,757,678	16,757,678
	每股盈餘	(0.63)	(0.55)
財務結構	負債占資產比率	61.59%	58.22%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	113.67%	122.40%
償債能力	流動比率	111.26%	134.89%
	速動比率	65.90%	89.53%

資料來源：108 年第二季為擬制整併後追溯重編之經會計師核閱簽證合併財務報表。
註：增資後之相關數據係依 108 年第二季募集資金推估。

本次計畫用於充實營運資金，業於 108 年第三季募集完成，預計在資金之挹注下，短期而言營業收入雖未增加，惟預計中長期將對本公司之營運規模擴展將有正面之助益。此外隨著 108 年第三季完成增資後，負債占資產比率亦隨著資產增加而降低至 58.22%，利息支出並無影響；在財務狀況方面，本公司流動比率及速動比率皆較 108 年第二季增資前的比率提升，提高自有資本比率，顯示本公司增資後較增資前已逐步健全財務結構，故本次增資效益應有合理顯現。

本次現金增資發行新股 400,000 仟股，占本公司增資後總股數 3,105,197 仟股之 12.88%，雖對每股盈餘產生一定之稀釋效果，惟其可使營運資金較靈活及降低負債比率。反之，若以銀行借款或發行普通公司債等籌資方式來支應未來營運所需，除利息負擔將降低公司整體獲利外，本金到期還本之資金壓力亦將嚴重影響營運資金正常供應。考量公司未來發展及財務負擔之影響，辦理現金增資發行新股以取得長期營運資金為較佳之籌資方式。

(三)110 年度現金增資案

1.計畫內容

(1)目的事業主管機關核准日期及文號:110 年 03 月 19 日金管證發字第 1100335468 號核准。

(2)計畫所需資金總額：新臺幣 12,000,984 仟元。

(3)資金來源：

A.現金增資發行普通股 300,000 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股溢價發行價格為新台幣 40 元，預計募集總金額為新台幣 12,000,000 仟元。

B.自有資金：984 仟元。

(4)計畫項目及資金運用情形：

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預訂完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度					
			110 年度		111 年度			
			第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施	111 年第四季	12,000,984	3,460,634	620,685	3,334,029	418,339	2,410,868	1,756,429

(5)本次計畫輸入證期局指定申報網站日期：110 年 3 月 19 日。

2.執形情形及效益分析

(1)執行情形

單位：新臺幣仟元

計畫項目	執行狀況		110 年度			111 年度				進度超前或落後情形、原因及改進計畫
			第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	
機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施	支用金額	預定	0	3,460,634	620,685	3,334,029	418,339	2,410,868	1,756,429	依設備付款條件支付
		實際	107,854	2,311,773	-	-	-	-	-	
	執行進度	預定	00%	28.84%	5.17%	27.78%	3.49%	20.09%	14.64%	
		實際	0.89%	19.26%	-	-	-	-	-	

(2)執行效益分析

本公司為因應未來營運發展規畫，本次募集資金主係用於購置機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施以擴充產能、提升生產製程及增進研發能力。截至公開說明書刊印日止，因相關設備仍處採購、安裝階段，故尚未具體產生執行效益。

二、本次現金增資、發行公司債、發行員工認股權憑證或限制員工權利新股計畫應記載事項：

(一)資金來源

1.計畫所需資金總額：新台幣 27,147,163 仟元。

2.資金來源：

(1)現金增資發行普通股 130,000 仟股，每股面額新金幣 10 元，競價拍賣底價（最低承銷價格）為每股新台幣 43 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購;惟均價新台幣 63.52 元高於最低承銷價格之 1.16 倍，故公開申購承銷價格以每股發行價格為新台幣 49.88 元溢價發行，預計募集總金額為新台幣 7,690,003 仟元。

(2)自有資金或銀行借款：19,457,160 仟元。

(3)如本次現金增資發行普通股每股實際發行價格因市場變動而與暫訂發行價格有異，致募集資金不足時，本公司將以自有資金及增加銀行借款金額因應；惟若募集資金增加時，則將減少銀行借款金額。

3.計畫項目及預定資金運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成時間	所需資金總額	預定資金運用時間								
			截至 110 年前三季(實際數)	110 年第四季(預計數)	111 年第一季(預計數)	111 年第二季(預計數)	111 年第三季(預計數)	111 年第四季(預計數)	112 年第一季(預計數)	112 年第二季(預計數)	112 年第三季(預計數)
P5 銅鑼廠建物廠房(土建/廠務)	112 年第三季	27,147,163	641,302	3,359,096	4,704,247	4,489,517	7,070,866	4,508,156	1,419,039	507,806	447,134

4.預計可能產生效益

本公司本次募資計畫，預計用於擴建廠房，主要用以解決目前廠房空間不足的問題外，同時考量未來產能及擴產所需，並配合自動化生產線之設置，以提高公司整體競爭力；預計於竹科銅鑼園區興建兩座晶圓廠，共計 53,000 平方公尺的無塵室面積，最大產能為 10 萬片/月，規劃於 10 年內分階段投資，並視市場需求及公司財務能力逐步擴充產能，預估總投資金額達新臺幣 2,780 億元。依本公司與銀行團簽訂之聯貸合約，聯貸案的借款利率約 1.7895%，本次募集資金新台幣 7,690,003 仟元一年預計可為公司節省利息支出 137,613 仟元，且自行興建可達到最佳的空間規劃與節省改建支出。

(二)本次發行公司債者，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法。如有委託經本會核准或認可之信用評等機構評等者，並應揭露該機構名稱、評等日期及公司債信用評等結果。如附有轉換、交換或認股權利者，並應揭露發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形與對股東權益影響：不適用。

(三)本次發行特別股者，應揭露每股面額、發行價格、發行條件對特別股股東權益影響、股權可能稀釋情形、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項。如附有轉換權利或認股權利者，並應揭露發行及轉換辦法或認股辦法（含轉換前原特別股未分配之股息等權利義務於強制轉換後之歸屬）：不適用。

(四)上市或上櫃公司發行未上市或未上櫃特別股者，應揭露發行目的、不擬上市或上櫃原因、對現有股東及潛在投資人權益之影響及未來有無申請上市或上櫃之計畫：不適用。

(五)股票依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第五條規定核准在證券商營業處所買賣之公司發行新股者，應說明未來上市（櫃）計畫：本次辦理現金增資發行新股係供初次上市公司承銷之用，故不適用。

(六)本次發行員工認股權憑證者，應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法：不適用。

(七)本次發行限制員工權利新股者，應揭露限制員工權利新股之發行辦法：不適用。

(八)說明本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響。以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：

1.本次計畫之可行性

(1)法定程序之可行性

本次辦理上市前現金增資發行普通股計畫，業經 110 年 3 月 9 日董事會及 110 年 7 月 2 日股東常會決議通過辦理初次上市前現金增資提撥公開承銷案，並於 110 年 10 月 19 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，且授權董事長全權處理相關增資事宜。經查與「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令規定並無不符，並經律師對本次募集現金增資計畫之內容出具法律意見書，顯示本次現金增資發行普通股計畫確已符合相關法令之規定，故本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

(2)資金募集之可行性

本次現金增資發行新股 130,000 仟股，其中依公司法第二百六十七條規定保留百分之十五，計 19,500 仟股由員工認購，餘 110,500 仟股則依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十一條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七條之一規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，並按證券交易法第二十八條之一規定，於 110 年 7 月 2 日股東常會決議通過，排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用。

本次辦理現金增資發行新股係採部份競價拍賣，部份公開申購方式辦理，員工認購不足或放棄認購部分，將授權董事長按發行價格洽特定人認購之，而對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保資金募集完成，故本公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

(3)資金運用之可行性

本次預計募集資金新台幣 7,690,003 仟元，預計於 110 年第四季完成募集，資金運用進度係考量申報及募集資金所需之作業時程而定，於資金到位後，即可於 110 年第四季投入支應擴建廠房之土建/廠務資金需求，減輕公司財務負擔並進而滿足中長期營運規劃，本公司已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構 12 吋生產基地並命名為力積電 P5

廠，110 年 3 月 25 日 P5 廠動土典禮完成後，建廠正式展開。第一期規劃包含第一座晶圓廠、廠務棟及整個廠區(含第二座)的地下基礎建築，初步以月產能 3 萬片為目標，依據工程進度規劃，並配合興建作業時程進行預估資金運用計劃，故本次籌資計畫之資金運用應具可行性。

2.本次計畫之必要性

本次辦理現金增資發行新股係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 11 條規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，故本次辦理現金增資發行新股係配合主管機關初次上市新股承銷制度予以辦理，實有其必要性。

3.本次計畫之合理性

(1)資金運用計畫及預計進度之合理性

本公司本次募資計畫項目預計用於擴建廠房，銅鑼廠(P5 廠)長期規劃是以十年期建構雙子星式的 12 吋晶圓廠(共兩座)，月產能共計 10 萬片。第一期規劃包含第一座晶圓廠、廠務棟及整個廠區(含第二座)的地下基礎建築，初步以月產能 3 萬片為目標，預估土建/廠務資金需求為新臺幣 27,147,163 仟元，目前已與科技部新竹科學園區管理局簽訂土地租賃契約，取得確切期間之土地使用權，於 2021 年 3 月動土，係依據工程規劃進度，並配合與建作業時程進行預估資金運用計劃，評估其資金運用及預計進度尚屬合理。

(2)預計可能產生效益之合理性

本公司擴建廠房，主係因應未來營運產能日益不足之問題，預計於竹科銅鑼園區興建力積電 P5 廠 10 年內分階段投資，將視市場需求及公司財務能力逐步擴充產能，預估總投資金額達新臺幣 2,780 億元，將於竹科銅鑼園區，興建兩座晶圓廠，共計 53,000 平方公尺的無塵室面積，10 萬片/月的產能規劃，以本公司與銀行團簽訂之聯貸合約，聯貸案的借款利率約 1.7895%，本次募集資金新台幣 7,690,003 仟元一年預計可為公司節省利息支出 137,613 仟元，另依照本公司承租 8AD 廠及購買 8B 廠改建經驗，由於舊有建築物並非專門供晶圓廠使用，機台擺設位置、各工作站動線安排、樓地板荷重程度、倉儲與出貨動線等皆須要經過規劃與修改，依照建築物屬性不同，投入改建的資金也會有所不同。如果自行興建應可達到最佳的空間規劃與節省改建支出，故其預計可能產生效益應具合理性。

4.各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

本公司目前主要之籌資工具為現金增資及銀行借款。如以銀行借款融資增加利息支出將侵蝕公司獲利。而為配合初次上市公司以發行新股辦理對外公開承銷之政策，本公司本次擬辦理現金增資發行新股 130,000 仟股，占本公司擬掛牌股本 3,535,196 仟股之 3.68%，且預估本公司營運規模持續成長下，對每股盈餘稀釋程度應屬有限。

5.以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(九)說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式：請參閱本公開說明書「附件十七、股票承銷價格計算書」。

(十)資金運用概算及可能產生之效益

1.收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構（含總成本及單位成本）、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：

本公司本次增資用以擴建廠房之預計可能產生效益，請詳『參、二、(八)、3、(2)』之說明。

2.轉投資其他公司者，應列明下列事項：不適用。

3.充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：不適用。

4.購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：不適用。

5.購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

四、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

肆、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表及綜合損益表股東會

1.個體簡明資產負債表—國際財務報導準則

單位：新臺幣仟元

項目＼年度		最近五年度財務資料(註1及2)				
		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
流動資產		3,270,729	3,389,346	22,276,890	17,604,923	21,531,488
不動產、廠房及設備		1,809,386	3,086,749	40,687,127	47,358,384	47,213,504
無形資產		1,426	9,392	526,924	241,728	256,695
其他資產		199,861	595,822	4,040,211	7,973,035	9,708,969
資產總額		5,281,402	7,081,309	67,531,152	73,178,070	78,710,656
流動負債	分配前	1,537,572	1,635,447	18,568,041	15,603,200	17,356,453
	分配後	1,537,572	1,635,447	18,663,275	15,603,200	18,882,320
非流動負債		517,494	1,581,417	19,002,304	27,698,489	28,136,514
負債總額	分配前	2,055,066	3,216,864	37,570,345	43,301,689	45,492,967
	分配後	2,055,066	3,216,864	37,665,579	43,301,689	47,018,834
歸屬於母公司業主之權益		3,226,336	3,864,445	4,862,413	29,876,381	33,217,689
共同控制下前手權益		-	-	25,295,906	-	-
共同控制下後手權益		-	-	(197,512)	-	-
股本		2,500,000	3,063,642	3,586,674	31,051,965	31,051,965
資本公積		89,200	89,200	89,200	181,927	403,616
保留盈餘	分配前	645,089	662,594	1,190,499	(1,357,217)	1,762,496
	分配後	81,447	139,562	238,156	(1,357,217)	236,629
其他權益		(7,953)	49,009	(3,960)	(294)	(380)
庫藏股票		-	-	-	-	(8)
非控制權益		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	3,226,336	3,864,445	29,960,807	29,876,381	33,217,689
	分配後	3,226,336	3,864,445	29,865,573	29,876,381	31,691,822

註 1：105 至 106 年度財務資料係未追溯重編。

註 2：107 及 108 年度為自始合併追溯重編之財務資料。

2.合併簡明資產負債表—國際財務報導準則

單位：新臺幣仟元

項目＼年度		最近五年度財務資料(註1及2)					當年度截至110年09月30日財務資料
		105年	106年	107年	108年	109年	
流動資產		3,403,458	3,559,900	22,492,634	17,800,940	21,727,795	45,969,629
不動產、廠房及設備		1,844,242	3,131,551	40,688,694	47,362,848	47,218,447	49,318,378
無形資產		25,200	29,203	527,062	241,820	256,741	382,764
其他資產		55,415	396,893	4,040,211	7,974,046	9,711,050	10,792,508
資產總額		5,328,315	7,117,547	67,748,601	73,379,654	78,914,033	106,463,279
流動負債	分配前	1,540,072	1,638,597	18,827,451	15,862,223	17,638,074	(註3)21,460,713
	分配後	1,540,072	1,638,597	18,922,685	15,862,223	19,163,941	21,460,713
非流動負債		517,494	1,581,417	18,960,343	27,641,050	28,058,270	32,845,258
負債總額	分配前	2,057,566	3,220,014	37,787,794	43,503,273	45,696,344	(註3)54,305,971
	分配後	2,057,566	3,220,014	37,883,028	43,503,273	47,222,211	54,305,971
歸屬於母公司業主之權益		3,226,336	3,864,445	4,862,413	29,876,381	33,217,689	52,157,308
共同控制下前手權益		-	-	25,295,906	-	-	-
共同控制下後手權益		-	-	(197,512)	-	-	-
股本		2,500,000	3,063,642	3,586,674	31,051,965	31,051,965	34,051,962
資本公積		89,200	89,200	89,200	181,927	403,616	10,193,384
保留盈餘	分配前	645,089	662,594	1,190,499	(1,357,217)	1,762,496	(註3)7,915,241
	分配後	81,447	139,562	238,156	(1,357,217)	236,629	7,915,241
其他權益		(7,953)	49,009	(3,960)	(294)	(380)	(3,279)
庫藏股票		-	-	-	-	(8)	-
非控制權益		44,413	33,088		-	-	-
權益總額	分配前	3,270,749	3,897,533	29,960,807	29,876,381	33,217,689	(註3)52,157,308
	分配後	3,270,749	3,897,533	29,865,573	29,876,381	31,691,822	52,157,308

註1：105至106年度財務資料係未追溯重編。

註2：107及108年度為自始合併追溯重編之財務資料。

註3:110年上半年度盈餘分配業經董事會決議每股現金股利新臺幣0.65元,截至110年9月30日已發放完畢。

3.個體簡明綜合損益表—國際財務報導準則

單位：新臺幣仟元

年度 項目	最近五年度財務資料(註1及2)				
	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
營業收入	5,919,892	6,236,518	49,913,779	35,897,121	45,684,615
營業毛利	1,325,394	1,227,746	15,280,265	3,000,668	10,992,411
營業損益	723,267	662,803	8,880,090	(2,087,965)	5,738,267
營業外收入及支出	(74,502)	(38,307)	(243,461)	(529,772)	(944,469)
稅前淨利(損)	648,765	624,496	8,636,629	(2,617,737)	4,793,798
繼續營業單位本期淨利	649,436	595,046	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	649,436	595,046	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477
本期其他綜合損益(稅後淨額)	23,803	43,063	(12,043)	(111,219)	(86,850)
本期綜合損益總額	673,239	638,109	6,902,701	(2,754,403)	3,719,627
淨利歸屬於母公司業主	649,436	595,046	985,928	(1,480,370)	3,806,477
淨利歸屬於共同控制下前手權益	-	-	5,890,576	(1,162,814)	-
淨利歸屬於共同控制下後手權益	-	-	38,240	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	673,239	638,109	998,480	(1,551,814)	3,719,627
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益	-	-	5,892,189	(1,162,814)	-
綜合損益總額歸屬於共同控制下後手權益	-	-	12,032	(39,775)	-
每股盈餘	1.46	1.34	2.56	(0.94)	1.23

註 1：105 至 106 年度財務資料係未追溯重編。

註 2：107 至 108 年度為自始合併追溯重編之財務資料。

4.合併簡明綜合損益表—國際財務報導準則

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	最近五年度財務資料(註1及2)					當年度截至110年09月30日財務資料
	105年	106年	107年	108年	109年	
營業收入	5,919,892	6,236,632	49,913,779	35,897,121	45,684,615	45,865,144
營業毛利	1,325,394	1,227,165	15,280,265	3,000,668	10,992,411	18,013,039
營業損益	715,270	631,168	8,886,597	(2,098,779)	5,744,244	12,551,292
營業外收入及支出	(68,691)	(17,997)	(246,549)	(516,106)	(945,171)	(720,096)
稅前淨利(損)	646,579	613,171	8,640,048	(2,614,885)	4,799,073	11,831,196
繼續營業單位本期淨利	647,250	583,721	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477	9,891,995
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	647,250	583,721	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477	9,891,995
本期其他綜合損益(稅後淨額)	23,803	43,063	(12,043)	(111,219)	(86,850)	(2,899)
本期綜合損益總額	671,053	626,784	6,902,701	(2,754,403)	3,719,627	9,889,096
淨利歸屬於母公司業主	649,436	595,046	985,928	(1,480,370)	3,806,477	9,891,995
淨利歸屬於非控制權益	(2,186)	(11,325)	-	-	-	-
淨利歸屬於共同控制下前手權益	-	-	5,890,576	(1,162,814)	-	-
淨利歸屬於共同控制下後手權益	-	-	38,240	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	673,239	638,109	998,480	(1,551,814)	3,719,627	9,889,096
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(2,186)	(11,325)	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益	-	-	5,892,189	(1,162,814)	-	-
綜合損益總額歸屬於共同控制下後手權益	-	-	12,032	(39,775)	-	-
每股盈餘	1.46	1.34	2.56	(0.94)	1.23	3.07

註1：105至106年度財務資料係未追溯重編。

註2：107至108年度為自始合併追溯重編之財務資料。

(二)影響上述簡明財務報表作一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報告之影響

1.本公司於 108 年 05 月收購母公司力晶科技(股)公司之相關營業及淨資產，此交易係屬共同控制下之組織重組，並據以自始合併重編 108 年度之合併財務報告。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

1.最近五年度簽證會計師之姓名及其查核意見

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
105	勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立	修正式無保留意見
106	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、鍾鳴遠	無保留意見加其他事項段落
107	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、鍾鳴遠	無保留意見加其他事項段落
108	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、鍾鳴遠	無保留意見加其他事項段落
109	勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰、鍾鳴遠	無保留意見

2.最近五年度如有更換會計師之情事者，應列示公司、前任及繼任會計師對更換原因之說明：106 年度係配合會計師事務所內部組織調整。

(四)本國發行公司自公開發行後最近連續七年，或外國發行公司最近連續七年財務報告皆由相同會計師查核簽證者，應說明未更換會計師之原因、目前簽證會計師之獨立性暨公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施：無

(五)財務分析—國際財務報導準則

1.個體最近五年度財務分析及財務比率變動原因—採用國際財務報導準則

分析項目 \ 年度		最近五年度財務資料(註1及2)				
		105 年	106 年	107 年	108 年	109 年
財務結構(%)	負債占資產比率	38.91%	45.43%	55.63%	59.17%	57.80%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	206.91%	176.43%	120.34%	121.57%	129.95%
償債能力(%)	流動比率	212.72%	207.24%	119.97%	112.83%	124.05%
	速動比率	160.95%	150.93%	79.27%	67.67%	76.84%
	利息保障倍數	77.32	56.60	17.68	(3.59)	7.74
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.18	5.93	8.50	6.10	7.86
	平均收現日數(天)	59	62	43	60	47
	存貨週轉率(次)	6.09	6.38	5.39	5.01	4.88
	應付款項週轉率(次)	9.54	9.76	11.75	11.62	13.46
	平均銷貨日數(天)	60	57	68	73	75
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	3.23 次	2.55 次	1.32 次	0.82 次	0.97 次
	總資產週轉率(次)	1.21 次	1.01 次	0.82 次	0.51 次	0.60 次
獲利能力	資產報酬率(%)	13.31%	9.66%	11.90%	(3.17)%	5.72%
	權益報酬率(%)	21.83%	16.78%	23.37%	(8.83)%	12.07%
	稅前純益占實收資本比率(%)	25.95%	20.38%	240.80%	(8.43)%	15.44%
	純益率(%)	10.97%	9.54%	13.85%	(7.36)%	8.33%
	每股盈餘(元)	1.46	1.34	2.56	(0.94)	1.23
現金流量	現金流量比率(%)	72.76%	62.46%	69.77%	13.33%	55.53%
	現金流量允當比率(%)	234.67%	130.57%	84.05%	54.33%	75.84%
	現金再投資比率(%)	2.17%	2.25%	3.48%	0.74%	3.27%
槓桿度	營運槓桿度	570.04%	645.30%	425.99%	(1,163.22)%	597.77%
	財務槓桿度	100.74%	100.38%	105.41%	80.27%	113.18%

註 1：105 至 106 年度財務資料係未追溯重編。

註 2：107 及 108 年度為自始合併追溯重編之財務資料。

2.合併最近五年度財務分析及財務比率變動原因—採用國際財務報導準則

分析項目＼年度		最近五年度財務資料(註1及2)					當年度截至110年09月30日財務分析
		105年	106年	107年	108年	109年	
財務結構(%)	負債占資產比率	38.62%	45.24%	55.78%	59.29%	57.91%	51.01%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	205.41%	174.96%	120.23%	121.44%	129.77%	172.35%
償債能力%	流動比率	220.99%	217.25%	119.47%	112.22%	123.19%	214.20%
	速動比率	169.15%	160.80%	79.32%	67.79%	76.71%	172.90%
	利息保障倍數	77.06	55.58	17.36	(3.51)	7.65	22.65
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.18 次	5.93 次	8.50 次	6.10 次	7.86 次	7.99 次
	平均收現日數(天)	59	62	43	60	47	46
	存貨週轉率(次)	6.09 次	6.36 次	5.39 次	5.01 次	4.88 次	4.60 次
	應付款項週轉率(次)	9.54 次	9.76 次	11.75 次	11.62 次	13.46 次	13.54
	平均銷貨日數(天)	60	57	68	73	75	80
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	3.20 次	2.51 次	1.32 次	0.82 次	0.97 次	1.27 次
	總資產週轉率(次)	1.20 次	1.00 次	0.81 次	0.51 次	0.60 次	0.66 次
獲利能力	資產報酬率(%)	13.21%	9.41%	11.87%	(3.15)%	5.71%	14.84%
	權益報酬率(%)	21.60%	16.29%	23.37%	(8.83)%	12.07%	30.90%
	稅前純益占實收資本比率(%)	25.86%	20.01%	240.89%	(8.42)%	15.45%	46.33%
	純益率(%)	10.93%	9.36%	13.85%	(7.36)%	8.33%	21.57%
	每股盈餘(元)	1.46	1.34	2.56	(0.94)	1.23	3.07
現金流量	現金流量比率(%)	71.97%	60.54%	68.88%	13.02%	54.64%	74.54%
	現金流量允當比率(%)	233.55%	129.25%	84.14%	54.31%	75.83%	95.77%
	現金再投資比率(%)	2.15%	2.19%	3.49%	0.73%	3.27%	4.07%
槓桿度	營運槓桿度	576.41%	677.66%	425.68%	(1,157.33)%	596.73%	298.83%
	財務槓桿度	100.75%	100.40%	105.53%	80.04%	113.39%	104.38%

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

(1) 利息保障倍數增加：主係 108 年稅前為淨損所致。

(2) 應收款項週轉率增加及平均收現日數減少：主係 109 年銷售單價上升及銷售數量增加致營業收入增加，且增加之幅度較 109 年平均應收帳款增加之幅度大所致。

(3) 資產報酬率、權益報酬率及稅前純益占實收資本比率增加：主係 109 年銷售數量上升致營業收入增加，且產能利用率上升，營業毛利增加，使稅後由 108 年稅後淨損轉為稅後淨利所致。

(4) 純益率增加：主係 109 年銷售數量上升致營業收入增加，且產能利用率上升，營業毛利增加，使 109 年由稅後虧損轉盈餘所致。

(5) 每股盈餘增加：主係 109 年銷售數量上升致營業收入增加，且產能利用率上升，營業毛利增加，使 109 年由稅後虧損轉盈餘所致。

(6) 現金流量比率增加：主係 109 年營業活動淨現金流入較 108 年同期增加之幅度，較 109 年流動負債較 108 年同期增加之幅度高所致。

(7) 現金流量允當比率增加：主係 109 年最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)較 108 年同期增加之幅度，較 109 年最近五年度營業活動淨現金流量較 108 年同期增加之幅度低所致。

(8) 現金再投資比率增加：主係 109 年因營業活動淨現金流入較 108 年增加所致。

(9) 營運槓桿度財務槓桿度及增加：主係 109 年銷售單價上升及銷售數量增加致營業收入增加，且產能利用率上升，營業毛利增加，使營業淨利較 108 年同期增加所致。

註 1：105 至 106 年度財務資料係未追溯重編。

註 2：107 及 108 年度為自始合併追溯重編之財務資料。

分析項目之比率計算說明：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝(權益總額＋非流動負債)／ 不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付費用)／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×(１－稅率)〕／ 平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝(歸屬於母公司業主之損益－特別股股利)／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／ 營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益 ／ (營業利益－利息費用)。

(六)會計科目重大變動說明

比較最近二年度資產負債表及綜合損益表之會計科目，若金額變動達百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者，應詳予分析其變動原因

1.個體財務報告最近兩年度會計科目重大變動說明

年度 會計項目	108 年 度	109 年 度	增 減 變 動		說 明
	金 額	金 額	金 額	%	
現金及約當現金	3,977,560	6,229,961	2,252,401	56.63	主要係 109 年為稅前淨利及存入保證金增加，抵銷部分取得不動產、廠房及設備、償還長期借款、發放現金股利、應收帳款及存貨增加之現金流出數所致。
存貨	6,385,497	7,818,611	1,433,114	22.44	主要係 109 年在製品、原料增加所致。
流動資產總計	17,604,923	21,531,488	3,926,565	22.30	主要係因 109 年業績增長，使現金增加且增加備貨所致。
使用權資產	4,393,945	7,182,770	2,788,825	63.47	主要係 109 年使用權資產-機器設備增加所致。
預付設備款	1,540,275	90,063	(1,450,212)	(94.15)	主要係 109 年尚未取得之設備之預付需求減少，使預付設備款下降所致。
一年內到期之長期借款	5,512,049	7,065,983	1,553,934	28.19	主要係 109 年中長期借款一年內到期之長期借款增加所致。
流動負債總計	15,603,200	17,356,453	1,753,253	11.24	主要係 109 年中長期借款一年內到期之長期借款增加所致。
長期借款	21,163,213	16,746,018	(4,417,195)	(20.87)	主要係 109 年償還銀行長期借款所致。
遞延所得稅負債	620,586	2,008,828	1,388,242	223.70	主要係 109 年不動產廠房及設備產生之暫時性差異增加所致。
租賃負債－非流動	4,083,303	6,659,024	2,575,721	63.08	主要係 109 年使用權資產-機器設備之租賃負債增加所致。
存入保證金	329,221	1,242,461	913,240	277.39	主要係 109 年客戶產能保證金增加所致。
未分配盈餘	(1,595,372)	1,695,690	3,291,062	(206.29)	主要係 109 年為淨利及發放現金股利所致。
保留盈餘總計	(1,357,217)	1,762,496	3,119,713	(229.86)	主要係 109 年為淨利及發放現金股利所致。
權益總計	29,876,381	33,217,689	3,341,308	11.18	主要係 109 年為淨利及發放現金股利所致。
營業收入淨額	35,897,121	45,684,615	9,787,494	27.27	主要係 109 年銷售數量增加，使營業收入增加所致。
營業毛利	3,000,668	10,992,411	7,991,743	266.33	主要係 109 年銷售單價上升及銷售數量增加，使營業收入增加，且產能利用率上升，故毛利亦增加所致。
營業利益	(2,087,965)	5,738,267	7,826,232	(374.83)	主要係 109 年營業毛利增加，致由營業淨損轉營業淨利。
稅前淨利	(2,617,737)	4,793,798	7,411,535	(283.13)	主要係 109 年營業利益增加，致由稅前淨損轉稅前淨利。
所得稅費用	(25,447)	(987,321)	(961,874)	3,779.91	主要係 109 年稅前淨利增加所致。
本年度淨利	(2,643,184)	3,806,477	6,449,661	(244.01)	主要係 109 年稅前淨利增加所致。
本年度綜合損益總額	(2,754,403)	3,719,627	6,474,030	(235.04)	主要係 109 年淨利增加所致。

2.合併財務報告最近兩年度會計科目重大變動說明

年度 會計項目	108 年 度	109 年 度	增 減 變 動		說 明
	金 額	金 額	金 額	%	
現金及約當現金	4,171,645	6,421,984	2,250,339	53.94	主要係 109 年為稅前淨利及存入保證金增加，抵銷部分取得不動產、廠房及設備、償還長期借款、發放現金股利、應收帳款及存貨增加之現金流出數所致。
存貨	6,385,497	7,818,611	1,433,114	22.44	主要係 109 年在製品、原料增加所致。
流動資產總計	17,800,940	21,727,795	3,926,855	22.06	主要係因 109 年業績增長，使現金增加且增加備貨所致。
使用權資產	4,393,945	7,182,770	2,788,825	63.47	主要係 109 年使用權資產-機器設備增加所致。
預付設備款	1,540,275	90,063	(1,450,212)	(94.15)	主要係 109 年尚未取得之設備之預付需求減少，使預付設備款下降所致。
一年內到期之長期借款	5,512,049	7,065,983	1,553,934	28.19	主要係 109 年中長期借款一年內到期之長期借款增加所致。
流動負債總計	15,862,223	17,638,074	1,775,851	11.20	主要係 109 年中長期借款一年內到期之長期借款增加所致。
長期借款	21,163,213	16,746,018	(4,417,195)	(20.87)	主要係 109 年償還銀行長期借款所致。
遞延所得稅負債	620,586	2,008,828	1,388,242	223.70	主要係 109 年不動產廠房及設備產生之暫時性差異增加所致。
租賃負債－非流動	4,083,303	6,659,024	2,575,721	63.08	主要係 109 年使用權資產-機器設備之租賃負債增加所致。
存入保證金	329,221	1,242,461	913,240	277.39	主要係 109 年客戶產能保證金增加所致。
未分配盈餘	(1,595,372)	1,695,690	3,291,062	(206.29)	主要係 109 年為淨利及發放現金股利所致。
保留盈餘總計	(1,357,217)	1,762,496	3,119,713	(229.86)	主要係 109 年為淨利及發放現金股利所致。
權益總計	29,876,381	33,217,689	3,341,308	11.18	主要係 109 年為淨利及發放現金股利所致。
營業收入	35,897,121	45,684,615	9,787,494	27.27	主要係 109 年銷售數量增加，使營業收入增加所致。
營業毛利	3,000,668	10,992,411	7,991,743	266.33	主要係 109 年銷售單價上升及銷售數量增加，使營業收入增加，且產能利用率上升，故毛利亦增加所致。
營業利益	(2,098,779)	5,744,244	7,843,023	(373.69)	主要係 109 年營業毛利增加，致由營業淨損轉營業淨利。
稅前淨利	(2,614,885)	4,799,073	7,413,958	(283.53)	主要係 109 年營業利益增加，致由稅前淨損轉稅前淨利。
所得稅費用	(28,299)	(992,596)	(964,297)	3,407.53	主要係 109 年稅前淨利增加所致。
本年度淨利	(2,643,184)	3,806,477	6,449,661	(244.01)	主要係 109 年稅前淨利增加所致。
本年度綜合損益總額	(2,754,403)	3,719,627	6,474,030	(235.04)	主要係 109 年淨利增加所致。

二、財務報表應記載事項

(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告

1.一〇八年度合併財務報告及會計師查核報告：請參閱附件一。

2.一〇九年度合併財務報告及會計師查核報告：請參閱附件二。

3.一一〇年第三季合併財務報告及會計師核閱報告：請參閱附件三。

(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告，但不包括重要會計項目明細表

1.一〇八年度個體財務報告及會計師查核報告：請參閱附件四。

2.一〇九年度個體財務報告及會計師查核報告：請參閱附件五。

(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無。

三、財務概況其他重要事項

(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露資訊：無。

(三)期後事項：無。

(四)其他：無。

四、財務狀況及經營結果之檢討分析

(一)財務狀況

單位：新臺幣仟元

年度 項目	108 年	109 年	差異	
			金額	%
流動資產	17,800,940	21,727,795	3,926,855	22%
不動產、廠房及設備	47,362,848	47,218,447	(144,401)	0%
無形資產	241,820	256,741	14,921	6%
其他資產	7,974,046	9,711,050	1,737,004	22%
資產總額	73,379,654	78,914,033	5,534,379	8%
流動負債	15,862,223	17,638,074	1,775,851	11%
非流動負債	27,641,050	28,058,270	417,220	2%
負債總額	43,503,273	45,696,344	2,193,071	5%
歸屬於母公司業主之權益	29,876,381	33,217,689	3,341,308	11%
股　本	31,051,965	31,051,965	0	0%
資本公積	181,927	403,616	221,689	122%
保留盈餘	(1,357,217)	1,762,496	3,119,713	(230%)
其他權益	(294)	(380)	(86)	29%
庫藏股票	0	(8)	(8)	-
權益總額	29,876,381	33,217,689	3,341,308	11%

項目 \ 年度	108 年	109 年	差異	
			金額	%

1.變動原因說明：(變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者)
(1)流動資產增加：主要係109年現金及約當現金及存貨增加所致。
(2)其他資產增加：主要係109年使用權資產之機器設備增加所致。
(3)資本公積增加：主要係109年認列股份基礎給付交易產生之資本公積-員工認股權所致。
(4)保留盈餘減少：主要係109年產生稅後淨利及發放股東現金股利所致。
2.未來因應計劃：不適用。

(二)財務績效

1.經營結果比較分析(合併報表)

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	108 年	109 年	差異	
			金額	%
營業收入	35,897,121	45,684,615	9,787,494	27%
營業成本	32,896,453	34,692,204	1,795,751	5%
營業毛利	3,000,668	10,992,411	7,991,743	266%
營業費用	5,272,132	5,460,494	188,362	4%
其他收益及費損淨額	172,685	212,327	39,642	23%
營業損益	(2,098,779)	5,744,244	7,843,023	(374%)
營業外收入及支出	(516,106)	(945,171)	(429,065)	83%
稅前淨利	(2,614,885)	4,799,073	7,413,958	(284%)
所得稅費用	(28,299)	(992,596)	(964,297)	3408%
本期淨利(損)	(2,643,184)	3,806,477	6,449,661	(244%)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(111,219)	(86,850)	24,369	(22%)
本期綜合損益總額	(2,754,403)	3,719,627	6,474,030	(235%)
淨利歸屬於本公司業主	(1,480,370)	3,806,477	5,286,847	(357%)
淨利歸屬於共同控制下前手權益	(1,162,814)	-	1,162,814	(100%)
綜合損益總額歸屬於本公司業主	(1,551,814)	3,719,627	5,271,441	(340%)
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益	(1,162,814)	-	1,162,814	(100%)
綜合損益總額歸屬於共同控制下後手權益	(39,775)	-	39,775	(100%)

1.變動達 20%以上之主要原因：
(1)營業收入增加：主要係109年全球半導體貿易需求增加，銷售單價上升及銷售數量增加，使營業收入增加所致。
(2)營業毛利增加：主要係109年銷售單價上升及銷售數量增加，使營業收入增加，且產能利用率上升，故毛利亦增加所致。
(3)其他收益及費損淨額增加：主要係109年其他收入增加。
(4)營業損益增加：主要係109年營業毛利增加，致由營業淨損轉營業淨利。
(5)營業外收入及支出減少：主要係109年財務成本及兌換淨損較108年增加所致。
(6)稅前淨利增加：主要係109年營業毛利增加，致由稅前淨損轉稅前淨利。
(7)所得稅費用增加：主要係109年稅前淨利增加所致。
(8)本期淨利增加：主要係109年營業毛利增加，致由淨損轉淨利。
(9)本期其他綜合損益增加：主要係109年認列確定福利計畫之再衡量數損失減少所致。
(10)本期綜合損益總額增加：主要係109年營業毛利增加，致綜合損益總額增加。
(11)淨利歸屬於本公司業主增加：主要係母公司109年營業毛利增加，致母公司由淨損轉淨利。
(12)淨利歸屬於共同控制下前手及後手權益增加：該科目係因108年組織重組而產生。

項目＼年度	108 年	109 年	差異	
			金額	%

(13)綜合損益總額歸屬於本公司業主增加：主要係母公司109年營業毛利增加，致母公司綜合損益總額轉正。

(14)綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益增加：該科目係因108年組織重組而產生。

(15)綜合損益總額歸屬於共同控制下後手權益增加：該科目係因108年組織重組而產生。

2.對未來財務業務之可能影響：無重大影響。

3.未來因應計劃：不適用。

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

銷售數量係依據本公司年度銷售目標、市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形等因素，並參酌本公司之產能規模而合理編製而成，預估本公司業績將呈穩定成長趨勢，可對財務業務狀況帶來正面助益。

(三)現金流量

1.最近年度(109年度)現金流量變動分析說明

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	108 年度	109 年度	增減比例
營業活動	2,064,801	9,638,179	7,573,378
投資活動	(12,640,448)	(3,358,321)	9,282,127
籌資活動	7,567,665	(4,029,432)	(11,597,097)

1.109 年度現金流量變動情形分析說明：

(1)營業活動：本期營業活動淨現金流入增加 7,573,378 仟元，主係 109 年營業收入增加，產生稅後淨利而 108 年為稅後淨損所致。

(2)投資活動：本期投資活動淨現金流出減少 9,282,127 仟元，主係 109 年取得不動產、廠房及設備之現金流出較 108 年減少所致。

(3)籌資活動：本期融資活動淨現金流出增加 11,597,097 仟元，主係 109 年舉借長期借款較 108 年減少及 108 年現金增資所致。

2.流動性不足之改善計畫：無此情事。

3.未來一年(110年度)現金流量變動分析說明

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額	預計全年度來自營業活動淨現金流量	預計全年度來自投資及籌資活動現金流量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
6,229,961	26,572,474	8,372,193	41,174,628	無	無

1.未來一年(110 年度)現金流動性分析：

(1)營運活動淨現金流入：預期客戶需求穩定成長，與正常投產計畫下所產生之淨現金流入。

(2)投資活動淨現金流出：主係擴充產能、產能調配、開發新製程而增購設備與擴建廠房支出。

(3)融資活動淨現金流出：主係現金增資、銀行長期借款舉借，扣除償還借款及支付使用權資產租賃支出等之淨現金流入。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響

單位：新臺幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	實際或預計資金運用情形
		110 年度
8 吋廠設備添購及汰換、廠房購置	自有資金或銀行貸款或現金增資所得之款項	2,334,396
12 吋廠產能調整、研發專案	自有資金或銀行貸款或現金增資所得之款項	6,618,391
P5 銅鑼廠建廠案	自有資金或銀行貸款或現金增資所得之款項	3,874,636
對財務業務之影響：本公司重大資本支出主要為 8 吋及 12 吋廠產能擴充或調配、P5 銅鑼建廠案及研發專案等，係以自有資金或銀行融資或由 110 年度現金增資所得之款項支應，其對財務業務並無重大影響。		

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1.轉投資政策

本公司目前主要營運活動聚焦在半導體晶圓代工事業，因此轉投資政策相對保守，如有投資也都以代工事業之相關投資標的為主，並不會從事其他行業之轉投資。本公司轉投資活動均由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序均由董事會或股東會討論通過。

2.最近轉投資事業獲利或虧損之主要原因、改善計畫

單位：新臺幣仟元

項目 轉投資事業名稱	認列利益 109 年度	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Global Powertec Co., Ltd	(20,719)	主要係匯兌損失及估列費用增加	-
PowerMemory Inc.	(1,802)	承接的設計開發業務量還不足以支持營業費用	-
Maxram Inc.	2,127	-	-

3.未來一年投資計畫

展望未來，本公司的轉投資政策將配合公司代工事業之成長，轉投資重心將以有效取得公司成長所需之各項先進技術投資佈局為主。本公司長期之轉投資政策，係以保守穩健為原則，並配合公司長期發展策略進行本業相關之投資佈局。本公司將持續監督管理既有之轉投資公司，以達成預期之轉投資目標，強化整體投資績效。

(六)其他重要事項：無。

伍、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

(一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議

年度	內部控制制度改進建議	改善情形
107	無重大內部控制缺失	-
108	無重大內部控制缺失	-
109	無重大內部控制缺失	-

(二)最近三年度內部稽核發現之重大缺失及其改善情形：本公司內部稽核人員於執行稽核過程中，並無發現足以影響本公司營運之重大缺失。

(三)內部控制聲明書：請參閱本公開說明書附件六。

(四)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：本公司為股票初次申請上市，委託會計師專案審查內部控制，未有缺失事項，請參閱本公開說明書附件七。

二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

三、證券商承銷商評估總結意見：請參閱本公開說明書附件八。

四、律師法律意見書：請參閱本公開說明書附件九。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：不適用。

六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時，經金融監督管理委員會通知應自行改進事項之改進情形：無。

七、本次募集與發行有價證券於申報生效時，經金融監督管理委員會通知應補充揭露之事項：不適用。

八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形：不適用。

九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

十一、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書：請參閱本公開說明書附件十。

十二、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，推薦證券商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書：不適用。

十三、發行公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具承諾日後有往來時必無非常規交易：請參閱本公開說明書附件十一。

十四、發行公司於申請上市會計年度及其上一會計年度已辦理與辦理中之大量現金增資發行

新股，及是否產生相當效益之評估：請參閱本公開說明書參、發行計畫及執行情形。

十五、發行公司是否有與其他公司共同使用申請貸款額度：無此情事。

十六、發行公司有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人：無此情事。

十七、具有上市審查準則第六條之一所規定申請之公司者，應增列事項：不適用。

十八、具有上市審查準則第十六條所規定之公司者，應增加揭露資訊：不適用。

十九、發行公司有上市審查準則補充規定第十條或第二十六條所列各款情事者，應將該非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會：不適用。

二十、本國發行公司為普通申請公司債上市者，應增列事項：不適用。

二十一、充分揭露發行公司與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式：請參閱本公開說明書附件十七。

二十二、發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於申請公司股票上市後對財務報表可能之影響：請參閱本公開說明書附件十八與附件十九。

二十三、發行人視所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行人就目前營運狀況及本次發行有價證券後之未來發展，進行比較分析並出具意見者，應揭露該等專家之評估意見：無。

二十四、其他基於有關規定應出具之書面承諾或聲明：請參閱本公開說明書附件十二與附件十三。

二十五、其他必要補充說明事項

依臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 10 月 5 日臺證上一字第 1101805401 號函，應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項：

(一) 最近三年度及截至最近期業績變化之合理性

【公司說明】

本公司及子公司提供 12 吋及 8 吋晶圓專業代工服務，包括提供邏輯暨特殊應用產品及記憶體產品晶圓代工服務以世界級同步的技術，搭配國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的代工服務，以共創事業高峰。至今已陸續引進不同的代工客戶，客戶的產品可應用的範圍涵蓋了 3C 應用領域–電腦、無線通訊、消費性電子及車用電子等。最近三年度及申請年度上半年度之業績變化情形如下表：

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	2018 年度		2019 年度		2020 年度		2021 上半年度	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
營業收入	49,913,779	100.00	35,897,121	100.00	45,684,615	100.00	28,573,900	100.00
營業成本	34,633,514	69.39	32,896,453	91.64	34,692,204	75.94	18,082,416	63.28
營業毛利	15,280,265	30.61	3,000,668	8.36	10,992,411	24.06	10,491,484	36.72
營業費用	6,651,675	13.33	5,272,132	14.69	5,460,494	11.95	3,632,498	12.71
其他收益及費損淨額	258,007	0.52	172,685	0.48	212,327	0.46	208,430	0.73
營業利益	8,886,597	17.80	(2,098,779)	(5.85)	5,744,244	12.57	7,067,416	24.73
營業外收入及支出	(246,549)	(0.49)	(516,106)	(1.44)	(945,171)	(2.07)	(561,640)	(1.97)
稅前淨利	8,640,048	17.31	(2,614,885)	(7.28)	4,799,073	10.50	6,505,776	22.77
所得稅費用	(1,725,304)	(3.46)	(28,299)	(0.08)	(992,596)	(2.17)	1,031,922	3.61

本期淨利	6,914,744	13.85	(2,643,184)	(7.36)	3,806,477	8.33	5,473,854	19.16
母公司業主	985,928	1.98	(1,480,370)	(2.97)	3,806,477	7.63	5,473,854	19.16
共同控制下前手權益	5,890,576	11.80	(1,162,814)	(2.33)	-	-	-	-
共同控制下後手權益	38,240	0.08	-	-	-	-	-	-
每股(虧損)盈餘	2.56	-	(0.94)	-	1.23	-	1.75	-

資料來源：2018~2020 年度經會計師查核簽證之財務報告及 2021 上半年度經會計師核閱之合併財務報告。

1.公司所屬行業之產業概況

本公司及其子公司主係從事半導體晶圓代工服務，主要產品分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，為各種電子產品中不可或缺的關鍵原料。邏輯暨特殊應用產品晶圓代工產品包含高壓製程產品、分離式元件產品、CMOS 影像感測器產品、電源管理晶片產品及嵌入式非揮發記憶體產品等；記憶體產品晶圓代工產品包含動態隨機存取記憶體產品及快閃記憶體產品(NAND/NOR Flash)。該公司及其子公司所生產之產品主係應用於電腦產品(Computer)、通訊應用(Communication)、消費性電子(Consumer)及車用電子(Automotive)等電子終端產品，茲就本公司及其子公司產品概況說明為：

(1)全球半導體產業概況

半導體技術的發展可追溯到一百年以前，從 1960 年代開始將電晶體、電阻及電容放在一個小矽晶片上構成大而複雜的電路，甚至整個系統(如計算機、收音機、電視機)，堪稱半導體積體電路(Integrated circuit：IC)之先驅，並帶動了科技呈現跳躍式的發展。IC 晶片為所有設備或裝置的基礎，藉由編輯應用程式控制設備或裝置，不斷改變人類的生活。複雜的半導體晶片可以協助智慧型手機、汽車、使用網路、雲端數據、工業自動化、智能家庭和消費性電子產品的技術發展，反過來說，隨著對關鍵技術發展要求及需求的成長，對半導體的需求也呈現成長趨勢。另根據 WSTS 的預測，全球半導體市場預計將在 2021 年成長至 5,510 億美元，成長率為 25.1%，其中最大的成長貢獻來自記憶體產品(37.1%)，其次是類比產品(29.1%)和邏輯產品(26.2%)；2022 年，受記憶體產品兩位數成長的推動，全球半導體市場預計將成長 10.1%，達到 6,060 億美元。

全球半導體市場成長預估

Spring 2021 Q2 Update	Amounts in US$M			Year on Year Growth in %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Americas	95,366	115,868	129,773	21.3	21.5	12.0
Europe	37,520	47,440	51,138	-5.8	26.4	7.8
Japan	36,471	42,913	45,893	1.3	17.7	6.9
Asia Pacific	271,032	344,656	379,678	5.1	27.2	10.2
Total World - $M	440,389	550,876	606,482	6.8	25.1	10.1
Discrete Semiconductors	23,804	29,389	30,936	-0.3	23.5	5.3
Optoelectronics	40,397	43,137	44,967	-2.8	6.8	4.2
Sensors	14,962	18,666	19,790	10.7	24.8	6.0
Integrated Circuits	361,226	459,685	510,788	8.4	27.3	11.1
Analog	55,658	71,882	76,757	3.2	29.1	6.8
Micro	69,678	77,305	80,922	4.9	10.9	4.7
Logic	118,408	149,388	162,341	11.1	26.2	8.7
Memory	117,482	161,110	190,769	10.4	37.1	18.4
Total Products - $M	440,389	550,876	606,482	6.8	25.1	10.1

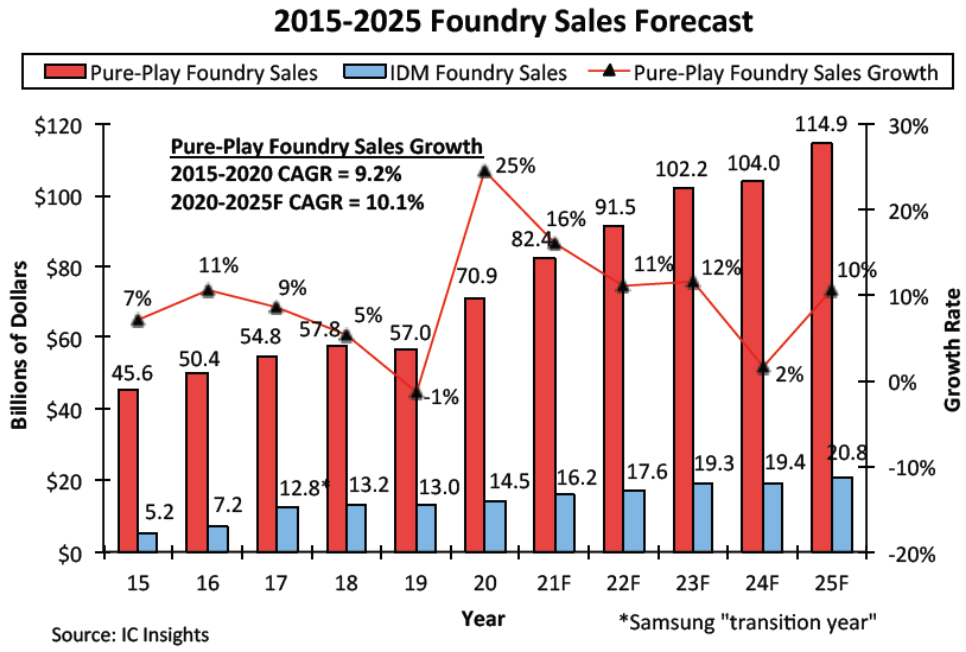
資料來源：WSTS

(2)晶圓代工產業概況

半導體之製程技術及產品良率與生產成本關係密切，故各廠商為達到規模經濟之生產，莫不致力於產品良率與製程技術之提昇。根據摩爾定律，每隔兩年晶片內之電晶體數目就會成長一倍，在近幾年製程進步速度加快下，其兩年之時間已縮短到一年半，因此本產業不但具有高度之技術水準，且技術變化速度亦相當快。

全球晶圓代工的模式興起於 1980 年代，由台灣積體電路製造股份有限公司開啟了專業晶圓代工之時代。邏輯晶圓主要用於智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子與消費性電子產品。

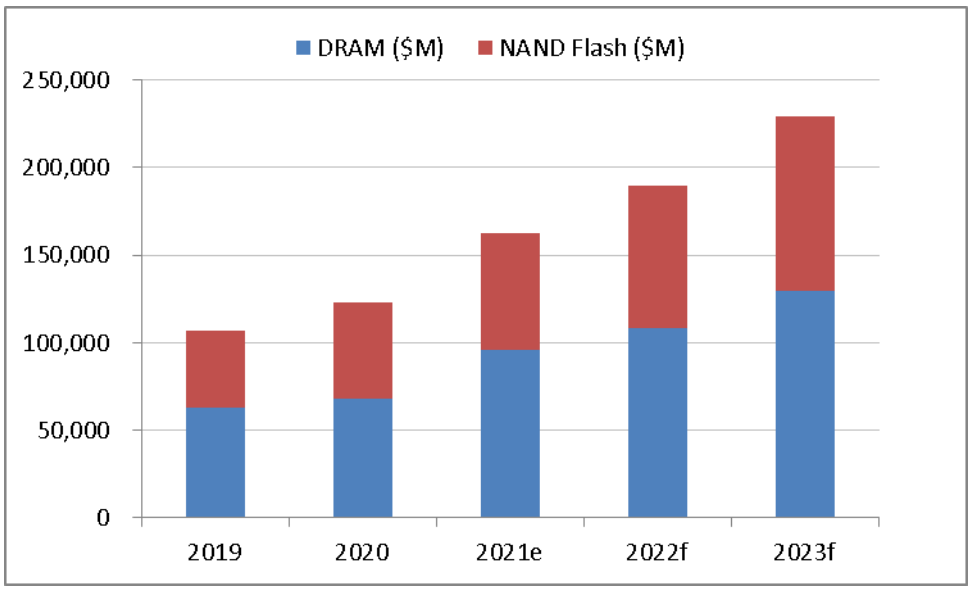
若以晶圓尺寸來區分，主要分為 8 吋及 12 吋，一般認為 12 吋晶圓優於 8 吋晶圓，係可提高晶圓代工廠的日產量。然而，8 吋晶圓的生產線非常成熟，部分晶圓代工廠設備已攤提完折舊，價格較具競爭優勢，生產主力為功率元件、電源管理 IC、影像感測器、指紋辨識晶片和顯示驅動 IC 等產品。根據 IC Insights 研究，在 5G 智慧型手機對應用處理器需求增加的推動下，純晶圓代工廠預計在 2021 年占晶圓代工廠總銷售額的 84%，從 2020 年到 2025 年，純晶圓代工廠的銷售預計達到複合年增長率 10.1%。



資料來源：IC Insights(2021/03)整理

(3)記憶體產業概況

記憶體晶圓之製成品，依產品別可分為「記憶體模組」(DRAM Module)及「快閃記憶卡」(Memory Card)兩大類，前者主要應用於筆記型電腦(Notebook, NB)、桌上型電腦(DT)、伺服器(Server)及工業電腦(Industrial Personal Computer, IPC)等產品，後者則多應用於如數位相機、智慧型手機、電子遊戲機、平板電腦及攝/錄影機等可攜式電子產品。根據 IC Insights 預測，全球記憶體市場預估在 2021 年成長至 1,626 億美元，成長率為 32.3%，2020~2025 年複合增長率則達 12.3%，其中 DRAM 與 NAND Flash 2020~2025 年複合增長率則分別為 12.5%及 12%。



資料來源：IC Insights，本公司整理(2021/06)

近年來，由於各大智慧型手機品牌商開始提高旗下手機 DRAM 的搭載率，以及美國、中國等主要國家加快大型資料中心的建置進程，而且為因應人工智慧(AI)、大數據(Big Data)、邊緣運算(Edge Computing)及伺服器(Server)等進階運用，因而對於 DRAM 及 NAND 型快閃記憶體(NAND Flash)有較顯著之需求。

2.營業收入

本公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業收入分別為 49,913,779 仟元、35,897,121 仟元、45,684,615 仟元及 28,573,900 仟元，營業收入成長率分別為(28.08)%、27.27%及 28.55%，2019 年度營業收入較前一年度降低 28.08%，主係中美貿易影響半導體產業之不確定性因素繼續蔓延，邏輯產品終端客戶拉貨需求降低，加上記憶體市況不佳、單位售價(ASP)下跌等因素影響，致當年度營業收入相較 2018 年度下降 28.08%。2020 年度營收較 2019 年度增加 9,787,494 仟元，成長幅度為 27.27%，主係邏輯 IC 出貨暢旺，且記憶體報價自谷底回溫，且本公司及其子公司透過優化客戶結構，營業收入亦隨之增加。2021 上半年度受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，此外，本公司及其子公司並透過優化客戶及產線組合，營業收入相較去年同期增加 28.55%。

3.營業毛利

本公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業毛利分別為 15,280,265 仟元、3,000,668 仟元、10,992,411 仟元及 10,491,484 仟元，分別較去年同期變化為(80.36)%、266.33%及 93.97%，營業毛利主要隨營收規模增減而變動，毛利率分別為 30.61%、8.36%、24.06%及 36.72%。2019 年度營業毛利較 2018 年度減少 12,279,597 仟元，減少幅度 80.36%，主係半導體產業呈現衰退趨勢致整體訂單減少、單位售價(ASP)下跌，整體產能使用率下降，使得產品之單位成本上升，導致營業毛利及毛利率下降。2020 年度營業毛利較 2019 年度增加 7,991,743 仟元，成長幅度達 266.33%，主要受惠於終端市場的需求使訂單增加，產能利用率提升、單位售價(ASP)回升及持續推進製程技術所致。2021 上半年度營業毛利較去年同期

增加 5,082,542 仟元，成長幅度 93.97%，主係受惠產能利用率滿載、持續推進製程技術以降低成本，及晶圓代工及記憶體漲價效應，持續推升毛利率所致。

4.營業利益

本公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業費用分別為 6,651,675 仟元、5,272,132 仟元、5,460,494 仟元及 3,632,498 仟元，營業費用率分別為 13.33%、14.69%、11.95%及 12.71%；2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業(損)益分別為 8,886,597 仟元、(2,098,779)仟元、5,744,244 仟元及 7,067,416 仟元，營業利(損)益率分別為 17.80%、(5.85)%、12.57%及 24.73%。

推銷費用主要係為業務人員之薪資及相關費用、園區管理費、間接材料及折舊費用等，2019 年度推銷費用相較 2018 年度減少 161,135 仟元，主要係 2019 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金及員工酬勞等帳列薪資費用減少 128,315 仟元，及園區管理費減少 29,359 仟元。2020 年推銷費用增加 34,428 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 17,530 仟元且因營收成長致園區管理費增加 18,236 仟元所致。2021 上半年度推銷費用相較去年同期增加 67,842 仟元，主係因業績成長，獎金及員工認股權增加 18,683 仟元，另因調薪及人員增加本薪增加 8,465 仟元。園區管理費較前期增加 12,398 仟元，員工酬勞前期增加 19,175 仟元。

管理費用主要係間接人員之薪資費用、折舊費用、環保費用、電腦使用費及專業服務費(勞務費)等，2019 年度管理費用減少 727,295 仟元，主係 2019 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 2018 年度減少 277,427 仟元，及員工酬勞減少 410,830 仟元。2020 年度管理費用減少 118,461 仟元，主係竹南廠於 2019 年 5 月前屬建廠期間，期間費用 318,118 仟元帳列管理費用，2019 年 6 月起帳列製造費用，故 2020 年管理費用減少。排除竹南廠建廠費用後，管理費用增加 199,657 仟元，主係獎金及員工酬勞增加。2021 上半年度管理費用相較去年同期增加 616,831 仟元，主係業績成長，獎金及員工認股權增加 256,438 仟元，另因調薪及人員增加至本薪增加 10,632 仟元，員工及董監酬勞增加 296,301 仟元，租金費用較前期增加 8,336 仟元，主係因公司銅鑼廠建廠所需短期租用銅鑼園區土地以作為土方暫存放置之用，致費用增加。

研究發展費用主要為研發人員之薪資費用、專業服務費、電腦使用費、製程及技術改善費用、折舊費用、光罩費用及間接材料等，2019 年度研究發展費用減少 491,113 仟元，主係 2019 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 2018 年度減少 516,765 仟元。2020 年研究發展費用增加 272,395 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 288,095 仟元所致。2021 上半年度研究發展費用相較去年同期增加 347,600 仟元，主係因業績成長，獎金及員工認股權增加 79,823 仟元，另因調薪及人員增加至本薪增加 38,299 仟元，員工酬勞增加 157,269 仟元。

其他收益及費損淨額主要為賠償收入、客戶產品開發服務收入、處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益(損失)、原物料零配件轉售收入、光罩代買收入、維修收入等。2018 年度其他收益及費損淨額 258,007 仟元主要係客戶產品開發服務收入；2019 年度其他收益及費損淨額 172,685 仟元，主係 8A 廠因電力中斷意外事故造成財產損失及營業中斷損失之保險理賠收入；2020 年度其他收益及費損淨額 212,327 仟元主要係客戶產品開發服務收入與處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益；2021 上半年度其他收益及費損淨額 208,430 仟元主要係處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益、原物料零配件轉售淨收入、維修收入、開發收入、光罩代買收入等。

綜上所述，本公司及其子公司營業費用變化，主係隨著該年度營收及稅前損益減少及增加，致間接人員之績效獎金、員工酬勞等薪資費用同幅增減變動所致。持續透過優化客戶及產線組合、推進製程技術、調升代工價格與產能利用率，使得營業利益率逐年成長，持續提升獲利能力。

5.營業外收入及支出變化原因及其合理性

本公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業外收入及支出分別為(246,549)仟元、(516,106)仟元、(945,171)仟元及(561,640)仟元，占營收比重分別為(0.49)%、(1.44)%、(2.07)%及(1.97)%，其主要項目為外幣兌換損益及銀行借款利息費用。由於本公司及子公司之銷售及採購材料係以美元計價，因此對美元部位產生匯率變動之曝險，並受匯率波動影響產生外幣兌換損益。另由於本公司及子公司為因應整體產業及客戶訂單快速成長，營運資金需求增加及增建銅鑼廠資金需求，故向銀行辦理借款產生之利息費用。綜上所述，本公司及子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業外收入及支出之變化，除與銀行借款餘額有關之外，主要係因匯率波動而產生之匯兌損益，其餘各項營業外收入及支出皆係由正常營運所產生。

6.稅前淨利變化原因及其合理性

本公司於 2019 年進行母子問組織重組，因屬共同控制下之組織重組，應視為自始即已合併而追溯 2018 年合併財務報告，產生共同控制下前手權益及共同控制下後手權益。

本公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之稅前淨利分別為 8,640,048 仟元、(2,614,885)仟元、4,799,073 仟元及 6,505,776 仟元，占營收淨額分別為 17.31%、(7.28)%、10.50%及 22.77%，在營業費用及營業外收支占營業收入比重並未有大幅變動之情況下，稅前淨利之變化主係受營業毛利變動所影響。2019 年度稅前虧損主係 2019 年度半導體產業呈現衰退趨勢致整體訂單減少、單位售價(ASP)下跌，整體產能使用率下降，使得產品之單位成本上升，導致營業毛利及毛利率下降。2020 年度營業毛利較 2019 年度增加 7,991,743 仟元，成長幅度達 266.33%，主要受惠於終端市場的需求使訂單增加，產能利用率提升、單位售價(ASP)回升及持續推進製程技術所致。2021 上半年度營業毛利較去年同期增加 5,082,542 仟元，成長幅度 93.97%，主係受惠產能利用率滿載、持續推進製程技術以降低成本，及晶圓代工及記憶體漲價效應，持續推升毛利率致稅前淨利增加。綜上所述，本公司及子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之營稅前淨利變化，主係受上述營業毛利之變動所影響。

【承銷商說明】

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工，包含顯示高壓邏輯製程((High Voltage；主要應用於手機、平板、TV 及電子紙等驅動 IC 及觸控驅動 IC 等產品)、電源管理晶片產品(Power IC)、分離式元件產品(Discrete)、CMOS 影像感測器產品(CIS；CMOS Image Sensor)、嵌入式非揮發性記憶體之晶圓代工服務；以及記憶體產品晶圓代工，包含動態隨機存取記憶體產品(DRAM)、快閃記憶體產品(NAND Flash、NOR Flash)之晶圓代工服務。記憶體單位區分為片及顆，該公司及其子公司記憶體產品(片)主要是代工客戶之產品銷售，具有設計能力卻沒有製造工廠，需要在公司投片；記憶體產品(顆)主要是銷售公司所設計產品，非客戶設計，其主要目的用來銷售未設計此規格產品之客戶，當產能稼動率不佳時，亦可用於填補產能，增加公司現金收入，定價策略參考 DRAM 現貨市場價格而定價，價格隨市場波動較大。該公司及其子公司主要產品別分別為邏輯暨特殊應用

產品、記憶體產品(片)及記憶體產品(顆)，其最近期及最近三個會計年度銷售變動主係受到市場需求變化及客戶自身業績與產品狀況等因素影響，針對該公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之業績變化情形評估如下：

1.最近三年度及申請年度上半年度之產品別營業收入、營業成本及營業毛利變化說明

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度		2018 年度		2019 年度		2020 年度		2021 上半年度	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
營業收入	邏輯暨特殊應用產品	21,590,848	43.26	16,703,015	46.53	25,657,228	56.16	15,858,264	55.50
	記憶體產品(片)	16,337,034	32.73	10,809,807	30.11	14,049,468	30.75	8,060,943	28.21
	記憶體產品(顆)	11,985,897	24.01	8,384,299	23.36	5,977,919	13.09	4,654,693	16.29
	合計	49,913,779	100.00	35,897,121	100.00	45,684,615	100.00	28,573,900	100.00
營業成本	邏輯暨特殊應用產品	15,791,962	45.60	13,388,912	40.70	17,978,616	51.82	9,901,747	54.76
	記憶體產品(片)	10,671,327	30.81	8,655,511	26.31	10,873,832	31.35	5,780,245	31.97
	記憶體產品(顆)	8,170,225	23.59	10,852,030	32.99	5,839,756	16.83	2,400,424	13.27
	合計	34,633,514	100.00	32,896,453	100.00	34,692,204	100	18,082,416	100.00
營業毛利	邏輯暨特殊應用產品	5,798,886	37.95	3,314,103	110.45	7,678,612	69.85	5,956,517	56.77
	記憶體產品(片)	5,665,707	37.08	2,154,296	71.79	3,175,636	28.89	2,280,698	21.74
	記憶體產品(顆)	3,815,672	24.97	(2,467,731)	(82.24)	138,163	1.26	2,254,269	21.49
	合計	15,280,265	100.00	3,000,668	100.00	10,992,411	100.00	10,491,484	100.00

(1)邏輯暨特殊應用產品

該公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度邏輯暨特殊應用產品之營業收入分別為 21,590,848 仟元、16,703,015 仟元、25,657,228 仟元及 15,858,264 仟元，占整體營業收入淨額之比率分別為 43.26%、46.53%、56.16%及 55.50%。2019 年度邏輯暨特殊應用產品營業收入相較 2018 年度減少 4,887,833 仟元，降低幅度為 22.64%，主係因國際間貿易緊張氛圍帶來不確定性，且消費型裝置如液晶電視、筆記型電腦、平板電腦、智慧手機和其他主要應用的顯示模組需求已達到飽和，終端客戶拉貨意願降低，致整體需求減少，且 2019 年度平均單價相較 2018 年度亦呈現下滑。2020 年度邏輯暨特殊應用產品營業收入相較 2019 年度增加 8,954,213 仟元，成長幅度達 53.61%，受惠於 5G 產業、車用市場及人工智慧等應用需求增加，為半導體產業注入成長動能，致該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺，營收隨之大幅成長。2021 上半年度邏輯暨特殊應用產品營業收入相較去年同期增加 3,665,211 仟元，主係受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺。

該公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度邏輯暨特殊應用產品之營業成本分別為 15,791,962 仟元、13,388,912 仟元、17,978,616 仟元及 9,901,747 仟元，營業毛利分別為 5,798,886 仟元、3,314,103 仟元、7,678,612 仟元及 5,956,517 仟元，毛利率分別為 26.86%、19.84%、29.93%及 37.56%。2019 年度營業毛利較

2018 年度減少 2,484,783 仟元，變動比率為(42.85)%，毛利率由 26.86%下降至 19.84%，主係因邏輯暨特殊應用產品應用終端需求趨緩，訂單減少導致營業毛利及毛利率下降。2020 年度營業毛利較 2019 年度增加 4,364,509 仟元，變動比率為 131.70%，毛利率由 19.84%上升至 29.93%，主係受惠於半導體終端需求增長之效益，使訂單量增加、整體產能利用率提升，致營業成本下降，毛利率隨之上升。2021 上半年度營業毛利較去年同期增加 2,350,880 仟元，變動比率為 65.20%，毛利率大幅上升至 37.56%，主係全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能利用率達滿載、且報價隨之上揚所致。

(2)記憶體產品(片)

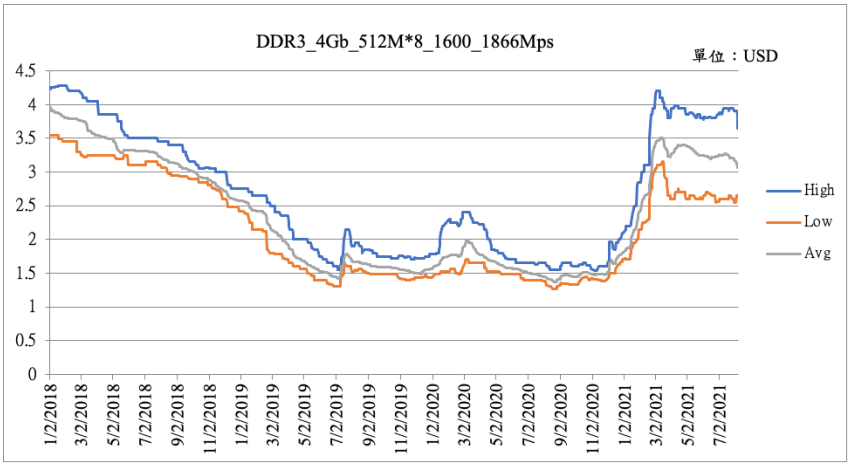
該公司及其子公司銷售之記憶體產品(片)主要係替具有設計能力卻沒有製造工廠客戶代工，2018~2020 年度及 2021 上半年度記憶體產品(片)之營業收入分別為 16,337,034 仟元、10,809,807 仟元、14,049,468 仟元及 8,060,943 仟元，占整體營業收入之比率分別為 32.73%、30.11%、30.75%及 28.21%。2019 年度記憶體產品(片)營業收入相較 2018 年度減少 5,527,227 仟元，降低幅度為 33.83%，主係 2018 年底客戶端與記憶體供應商的庫存水位皆達到相對高點，且 2019 年度受到美中貿易戰造成供應鏈趨於保守，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱，致記憶體價格及銷售量在 2019 年上半年度快速滑落。2020 年度記憶體產品(片)營業收入相較去年同期增加 3,239,661 仟元，變動幅度為 29.97%，主係由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，其中 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，且由於三大記憶體廠商(三星、SK 海力士、美光)在 2020 年下半年將舊製程 DRAM 產能移轉至 CMOS 影像感測器製程後，使得 DRAM 市場供給產生短缺，帶動需求增加所致。2021 上半年度記憶體產品(片)營業收入相較去年同期增加 945,169 仟元，變動幅度為 13.28%，主要受惠需求增加單位報價持續上揚。

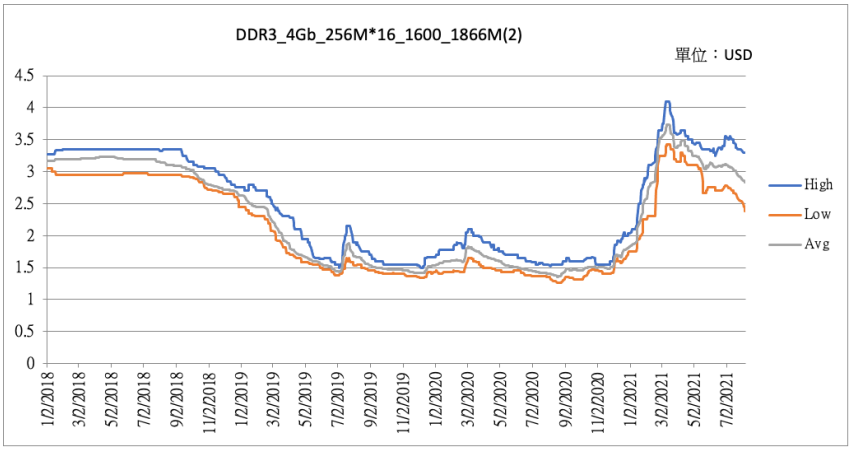
該公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度記憶體產品(片)之營業成本分別為 10,671,327 仟元、8,655,511 仟元、10,873,832 仟元及 5,780,245 仟元，營業毛利分別為 5,665,707 仟元、2,154,296 仟元、3,175,636 仟元及 2,280,698 仟元，毛利率分別為 34.68%、19.93%、22.60%及 28.29%，2019 年度營業毛利較 2018 年度減少 3,511,411 仟元，變動比率為(61.98)%，毛利率下降至 19.93%，主係因記憶體市場需求疲軟，處於供過於求的狀態，故該公司及其子公司訂單量減少、整體產能使用率大幅降低所致。2020 年度營業毛利較 2019 年度增加 1,021,340 仟元，變動比率為 47.41%，主係由於 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，使訂單量增加、整體產能利用率提升，致營業成本下降，毛利率成長至 22.60%。2021 上半年度除承接 2020 年度產業整體態勢外，且單位報價持續上揚，毛利率更進而成長至 28.29%。

(3)記憶體產品(顆)

該公司及其子公司銷售之記憶體產品(顆)主要是銷售該公司所設計產品，非客製化產品，2018~2020 年度及 2021 上半年度記憶體產品(顆)之營業收入分別為 11,985,897 仟元、8,384,299 仟元、5,977,919 仟元及 4,654,693 仟元，占整體營業收入之比率分別為 24.01%、23.36%、13.09%及 16.29%，主係為 PC DRAM 及包裝元件等。2019 年度記憶體產品(顆)之營業收入較 2018 年度減少 3,601,598 仟元，變動比率(30.05)%，主係 2019 年度因智慧型手機成長趨緩、終端需求降溫等因素，出現供過於求的狀況，致平均銷售價格(ASP)下跌。2020 年度由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，致記憶體市況雖至谷底回溫，惟 PC 應

用相關成長力道相對持平，且該公司及其子公司為逐漸降低記憶體價格波動過大產生之營運風險，2019 年度開始改變銷售產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，故記憶體銷售數量相較前一年度略為降低，致 2020 年度記憶體產品(顆)營業收入占整體營業收入比率降至 13.09%。2021 上半年度記憶體產品(顆)之營業收入相較去年同期增加 1,736,091 仟元，變動比率為 59.48%，主係標準型 DRAM 受惠於新冠肺炎疫情持續推動筆電出貨動能單位報價持續上揚所致。另查詢 TrendForce 最近三年度及最近期記憶體報價資料，市場趨勢與該公司及其子公司記憶體產品(顆)之營業收入變化尚無重大異常之情事。





該公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度記憶體產品(顆)之營業成本分別為 8,170,225 仟元、10,852,030 仟元、5,839,756 仟元及 2,400,424 仟元，營業毛利分別為 3,815,672 仟元、(2,467,731)仟元、138,163 仟元及 2,254,269 仟元，毛利率分別為 31.83%、(29.43)%、2.31%及 48.43%，2019 年度營業毛利較 2018 年度大幅減少 6,283,403 仟元，毛利率下降至(29.43)%，主係因記憶體市場需求疲軟，處於供過於求的狀態，故該公司及其子公司訂單量減少、整體產能使用率大幅降低所致，此外，記憶體產品(顆)主要應用之 PC DRAM 終端報價跌幅甚鉅，故毛利率呈現負數。2020 年度由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，致記憶體市況至谷底回溫，記憶體銷售單價(ASP)微幅上漲，但該公司為逐漸降低 DRAM 價格波動過大產生之營運風險，故改變銷售產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，記憶體(顆)之銷售數量因而減少以致銷售金額相較去年度下滑，但惟調整產能配置後使記憶體產線之產能利用率提升，致營業成本下降，毛利率由負轉為正。2021 上半年度受惠終端需求增溫、調整產能配置使產能利用率滿載致單位成本下降，加上單位報價持續上揚，故使毛利率大幅成長至 48.43%。

2.營業費用及營業利益變化說明

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	2018 年度		2019 年度		2020 年度		2021 上半年度	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
推銷費用	461,925	0.93	300,790	0.84	335,218	0.73	229,667	0.80
管理費用	2,736,267	5.48	2,008,972	5.60	1,890,511	4.14	1,499,885	5.25
研究發展費用	3,453,483	6.92	2,962,370	8.25	3,234,765	7.08	1,902,946	6.66
營業費用	6,651,675	13.33	5,272,132	14.69	5,460,494	11.95	3,632,498	12.71
其他收益及費損淨額	258,007	0.52	172,685	0.48	212,327	0.46	208,430	0.73
營業利益	8,886,597	17.80	(2,098,779)	(5.85)	5,744,244	12.57	7,067,416	24.73

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

(1)營業費用

該公司及其子公司之營業費用包括推銷費用、管理費用及研究發展費用，2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業費用分別為 6,651,675 仟元、5,272,132 仟元、5,460,494 仟元及 3,632,498 仟元，占營收比重分別為 13.33%、14.69%、11.95%及 12.71%，茲就營業費用之主要項目分別說明如下：

A.推銷費用

推銷費用主要係為業務人員之薪資及相關費用、園區管理費、間接材料及折舊費用等，2019 年度推銷費用相較 2018 年度減少 161,135 仟元，主要係 2019 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金及員工酬勞等帳列薪資費用減少 128,315 仟元，及園區管理費減少 29,359 仟元。2020 年推銷費用增加 34,428 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 17,530 仟元且因營收成長致園區管理費增加 18,236 仟元所致。2021 上半年度推銷費用相較去年同期增加 67,842 仟元，主係因業績成長，獎金及員工認股權增加 18,683 仟元，另因調薪及人員增加本薪增加 8,465 仟元。園區管理費較前期增加 12,398 仟元，員工酬勞前期增加 19,175 仟元。

B.管理費用

管理費用主要係間接人員之薪資費用、折舊費用、環保費用、電腦使用費及專業服務費(勞務費)等，2019 年度管理費用減少 727,295 仟元，主係 2019 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 2018 年度減少 277,427 仟元，及員工酬勞減少 410,830 仟元。2020 年度管理費用減少 118,461 仟元，主係竹南廠於 2019 年 5 月前屬建廠期間，期間費用 318,118 仟元帳列管理費用，2019 年 6 月起帳列製造費用，故 2020 年管理費用減少。排除竹南廠建廠費用後，管理費用增加 199,657 仟元，主係獎金及員工酬勞增加。2021 上半年度管理費用相較去年同期增加 616,831 仟元，主係業績成長，獎金及員工認股權增加 256,438 仟元，另因調薪及人員增加至本薪增加 10,632 仟元，員工及董監酬勞增加 296,301 仟元，租金費用較前期增加 8,336 仟元，主係因公司銅鑼廠建廠所需短期租用銅鑼園區土地以作為土方暫存放置之用，致費用增加。

C.研究發展費用

研究發展費用主要為研發人員之薪資費用、專業服務費、電腦使用費、製程及技術改善費用、折舊費用、光罩費用及間接材料等，2019 年度研究發展費用減少 491,113 仟元，主係 2019 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎

金等帳列薪資費用相較 2018 年度減少 516,765 仟元。2020 年研究發展費用增加 272,395 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 288,095 仟元所致。2021 上半年度研究發展費用相較去年同期增加 347,600 仟元，主係因業績成長，獎金及員工認股權增加 79,823 仟元，另因調薪及人員增加至本薪增加 38,299 仟元，員工酬勞增加 157,269 仟元。

D.其他收益及費損淨額

其他收益及費損淨額主要為賠償收入、客戶產品開發服務收入、處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益(損失)、原物料零配件轉售收入、光罩代買收入、維修收入等。2018 年度其他收益及費損淨額 258,007 仟元主要係客戶產品開發服務收入；2019 年度其他收益及費損淨額 172,685 仟元，主係 8A 廠因電力中斷意外事故造成財產損失及營業中斷損失之保險理賠收入；2020 年度其他收益及費損淨額 212,327 仟元主要係客戶產品開發服務收入與處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益；2021 上半年度其他收益及費損淨額 208,430 仟元主要係處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益、原物料零配件轉售淨收入、維修收入、開發收入、光罩代買收入等。

(2)營業利益

該公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業(損)益分別為 8,886,597 仟元、(2,098,779)仟元、5,744,244 仟元及 7,067,416 仟元，營業(損)益率分別為 17.80%、(5.85)%、12.57%及 24.73%。

該公司及其子公司於 2019 年度因整體產能利用率偏低，毛利率由 30.61%降至 8.36%，致營業利益率為負，而 2020 年度主係邏輯 IC 出貨暢旺，且記憶體報價自谷底回溫及該公司及子公司持續產品組合優化致營收成長，且成本費用控管得宜，致 2020 年度營業費用率下降至 11.95%，營業利益率成長至 12.57%。2021 上半年度隨著毛利率大幅上升至 36.72%，營業利益率隨之明顯增長至 24.73%，該公司及其子公司透過優化客戶及產線組合、推進製程技術、調升代工價格與產能利用率，使得營業利益率逐年成長，持續提升獲利能力，經評估應無重大異常。

3.營業外收入及支出變化說明

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度		2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 上半年度
		金額	金額	金額	金額
其他收入	利息收入	91,954	62,543	27,977	10,792
	股利收入	610	-	-	-
	小計	92,564	62,543	27,977	10,792
其他利益及損失	外幣兌換淨(損失)利益	166,282	(68,070)	(316,469)	(191,414)
	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(損失)利益	(39,512)	12,784	21,504	(18,855)
	小計	126,770	(55,286)	(294,965)	(210,269)
財務成本	借款之利息	(405,859)	(437,244)	(479,135)	(247,742)
	租賃負債之利息	-	(75,849)	(189,059)	(109,409)
	應付租賃款之利息	(49,562)	-	-	-
	其他	(10,462)	(10,270)	(9,989)	(5,012)
	小計	(465,883)	(523,363)	(678,183)	(362,163)
合計		(246,549)	(516,106)	(945,171)	(561,640)

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司之營業外收入及支出包括其他收入、其他利益及損失及財務成本，2018~2020 年度及 2021 上半年度之營業外收入及支出分別為(246,549)仟元、(516,106)仟元、(945,171)仟元及(561,640)仟元，占營收比重分別為(0.49)%、(1.44)%、(2.07)%及(1.97)%，茲就營業外收入及支出之主要項目分別說明如下：

(1)其他收入

該公司及其子公司業外之其他收入主係利息收入及股利收入，而以利息收入為主，2018~2020 年度及 2021 上半年度之利息收入 91,954 仟元、62,543 仟元、27,977 仟元及 10,792 仟元，主要係隨各年度銀行活期存款及定期存款產生之利息收入變動所致。

(2)其他利益及損失

該公司及其子公司業外之其他利益及損失主係外幣兌換損益及透過損益按公允價值衡量之金融資產利益(損失)，變動說明如下：

A.外幣兌換淨(損失)利益

該公司及其子公司於 2018~2020 年度及 2021 上半年度之兌換利益(損失)淨額分別為 166,282 仟元、(68,070)仟元、(316,469)仟元及(191,414)仟元，占營業收入之比率分別為 0.33%、(0.19%)、(0.69%)及(0.67%)，占營業淨利(損失)之比率則分別為 1.87%、(3.24%)、(5.51%)及(2.71%)；該公司及其子公司產生之兌換損益主要係美元銷貨所產生。2018 年度美國國內經濟增長強勁、聯準會持續升息，致美元平穩升值，進而產生淨兌換利益；2019 年度受到美國聯準會三度降息之影響，致美元貶值，進而產生淨兌換損失；2020 年度受到新冠肺炎疫情影響，對經濟產生巨大的衝擊，美國貨幣政策因此轉向寬鬆，且是無限量化寬鬆，致美元持續貶值，對於持有美元淨資產部位不利，因此持續產生兌換損失；2021 年上半年美元仍呈現貶值走勢，惟其兌換損失占營業收入比例已約略降至 0.67%。該公司及其子公司除透過主要往來銀行提供專業諮詢的服務，以掌握匯率走勢外，主係透過即期交易及遠期外匯合約來規避以非新臺幣計價之貨幣性資產與負債及高度可能發生之預期交易所產生之匯率風險，故匯率波動應不致於對該公司之財務業務產生重大影響。

B.透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(損失)利益

該公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(損失)利益分別為(39,512)仟元、12,784 仟元、21,504 仟元及(18,855)仟元，即是承作遠期外匯合約之已實現損益和期末評價所產生之未實現損益合計。

(3)財務成本

該公司及其子公司業外之財務成本主係借款利息費用及租賃負債利息，主以借款利息費用為主，2018~2020 年度及 2021 上半年度之借款利息費用分別為(405,859)仟元、(437,244)仟元、(479,135)仟元及(247,742)仟元，主要係隨各年度銀行借款產生之利息費用變動所致。

4.稅前淨利及每股盈餘變化說明

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	2018 年度 金額	2019 年度 金額	2020 年度 金額	2021 上半年度 金額
稅前淨利	8,640,048	(2,614,885)	4,799,073	6,505,776
所得稅費用	(1,725,304)	(28,299)	(992,596)	(1,031,922)
本期淨利	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477	5,473,854
加權平均流通在外股數	2,705,197	2,821,863	3,105,197	3,130,196
基本每股盈餘(元)	2.56	(0.94)	1.23	1.75

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 2018~2020 年度及 2021 上半年度之稅前淨利分別為 8,640,048 仟元、(2,614,885)仟元、4,799,073 仟元及 6,505,776 仟元；每股盈餘(虧損)分別為 2.56 元、(0.94)元、1.23 元及 1.75 元。該公司及其子公司 2019 年度稅前虧損主係 2019 年度半導體產業呈現衰退趨勢致整體訂單減少、單位售價(ASP)下跌，整體產能使用率下降，使得產品之單位成本上升，導致營業毛利及毛利率下降。2020 年度營業毛利較 2019 年度增加 7,991,743 仟元，成長幅度達 266.33%，主要受惠於終端市場的需求使訂單增加，產能利用率提升、單位售價(ASP)回升及持續推進製程技術所致。2021 上半年度營業毛利較去年同期增加 5,082,542 仟元，成長幅度 93.97%，主係受惠產能利用率滿載、持續推進製程技術以降低成本，及晶圓代工及記憶體漲價效應，持續推升毛利率致本期淨利增加。

整體而言，該公司及其子公司營運獲利仍穩定成長，稅前淨利及每股盈餘仍呈逐期上升之態勢，其變化情形應屬合理。

【會計師說明】

單位：新臺幣仟元

分析項目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度上半年度
營業收入	49,913,779	35,897,121	45,684,615	28,573,900
營業成本	34,633,514	32,896,453	34,692,204	18,082,416
營業毛利	15,280,265	3,000,668	10,992,411	10,491,484
營業毛利率	31%	8%	24%	37%

資料來源：力積電公司 2019、2020 年度、2021 年度第二季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報表，2018 年度為自始合併追溯重編之財務資料。

力積電公司為提供邏輯暨特殊應用產品及記憶體產品晶圓代工服務之專業晶圓代工廠，所提供之晶圓代工服務其電子終端產品應用於電腦產品、通訊應用、消費性電子及車用電子產品，銷售對象主要為半導體 IC 設計公司。

1.營業收入及毛利率變化說明

力積電公司 2018、2019、2020 年度、2021 年度上半年度營業收入分別為 49,913,779 仟元、35,897,121 仟元、45,684,615 仟元及 28,573,900 仟元。2019 年度受到全球 DRAM 市場結構供給過剩，由於上半年客戶群庫存調整又受到中美貿易摩擦再起的影響，整體智慧型手機、車用市場及物聯網產品需求有所減緩，導致代工訂單疲軟，市場價格亦受到波動下修，使得毛利率較前一年滑落 23%至 8%。而為因應 2019 年營運困境及全球實體經濟衝擊，力積電公司在 2019 年下半年進行調整企業經營架構並整合其晶圓廠產能資源，在 Covid-19 疫情影響全球經濟的 2020 年，力積電公司透過開發客製化代工技術及提高產能利用率，並在宅經濟和供應鏈重組的帶動下，受惠於全球各地採取隔離防疫措施，使得 NB、平板電腦及面板顯示器等消費需求增加，力積電公司 2020 年度之營收及獲利亦隨著銷售單價上漲及

銷售數量增加而大幅改善。而 2021 年上半年 DRAM 市場持續呈現供不應求，主要是由於疫情拉動遠距的商機，加上數位轉型 5G 及車用電子大量導入，市場相關合約價亦已陸續逐季漲價，因此使得 2021 上半年度銷售額及毛利率較 2020 年同期均呈現上升。

2.營業費用說明

力積電公司之推銷費用主係為業務人員之薪資費用、園區管理費、間接材料及折舊費用等。2019 年度推銷費用相較 2018 年度減少主要係 2019 年度係稅前虧損，使得各項獎金及員工酬勞等費用估列金額下降。2020 年推銷費用增加主係因營收成長，相對使獎金、員工酬勞及員工認股權等薪資費用以及園區管理費用增加所致。2021 上半年度推銷費用之薪資費用總計約 110,099 仟元，占整體推銷費用 48%，主係因業績成長，另因調薪及人員增加致使整體本薪幅度上升。

帳列管理費用主係間接人員之薪資費用、折舊費用、環保費用、電腦使用費及專業服務費等，2019 年度管理費用相較 2018 年度減少，主係 2019 年度為稅前淨損，故各項獎金及員工酬勞相較 2018 年度減少。2020 年度管理費用變化影響，主係部分建廠期間費用後續依其功能類別歸屬於製造費用，除此之外整體管理費用主要係獎金及員工酬勞等費用增加。2021 上半年度管理費用相較去年同期增加，主係員工酬勞估列因稅前淨利增加所致。另租金費用本期增加，主係因力積電公司銅鑼廠建廠所需短期租用銅鑼園區土地以作為土方暫存放置之用，致使相關管理費用增加。

研究發展費用主要為研發人員之薪資費用、專業服務費、電腦使用費、製程及技術改善費用、折舊費用、光罩費用及間接材料等。2020 年研究發展費用增加主係因稅前損益由虧轉盈，各項獎金、員工酬勞及員工認股權費用增加所致。2021 上半年度研究發展費用相較去年同期增加，主係因業績成長且因本期調薪及人員增加，使得薪資費用大幅成長。

帳列其他收益及費損淨額主係賠償收入、產品開發服務收入、不動產、廠房及設備處分淨利益(損失)及原物料零配件轉售收入等。2018 年度其他收益及費損淨額主係客戶產品開發服務收入。2019 年度帳列其他收益及費損淨額，主係廠區電力事故產生之保險理賠收入。2020 年度其他收益及費損淨額主要係客戶產品開發服務收入與處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益。2021 上半年度其他收益及費損淨額主係來自原物料零配件轉售收入 8,997 仟元、維修收入 8,028 仟元及產品開發服務收入 4,862 仟元。

(二) 2019 年增資收購原母公司力晶公司晶圓製造業務相關營業及淨資產，暨 2020 年原母公司力晶公司辦理減資以力積電股票抵充退還股款並規畫以力積電公司申請上市，其原因、程序之適法性、必要性及合理性。

【公司說明】

1.原因

(1)組織結構調整

為有效整合集團資源以提升生產動能進而提高整體競爭力，經由組織重組調整企業經營架構，藉以降低未來營運受全球總體經濟因素變遷之不確定性。本公司目前擁有三座 12 吋晶圓廠及二座 8 吋晶圓廠，組織結構調整後能整合 8 吋與 12 吋廠代工資源，提供客戶更有競爭力的產品。

(2)企業重新定位

本公司原為力晶公司自 2008 年分割成立，主要從事 8 吋晶圓代工相關業務，包括各式積體電路(DRAM / LCD Driver / Nor Flash / Power Management IC)之代工與銷售、開發、生產製造。本公司於 2018 年由鉅晶電子(股)公司更名為力晶積成電子製造(股)公司，透過明確產業定位及多元化，強化專業分工，並降低景氣循環之影響，追求穩定獲利，以上下合擊的策略重新塑造為世界級半導體公司。

(3)健全財務體質

透過組織調整無須背負以往力晶公司向銀行紓困之歷史包袱，本公司可善用多重籌資管道，增加未來產能擴張所需的資金調度彈性，並能逐漸展開股東增資循環，有效降低往來銀行風險。同時，專注於本業，降低過多業外轉投資帶來營運風險。

2.程序之適法性

(1)收購原母公司力晶公司晶圓製造業務相關營業

本公司業經 2018 年 9 月 4 日第六屆第四次董事會決議通過，依企業併購法第 28 條規定進行母子間組織重組，收購力晶科技股份有限公司(以下簡稱”力晶公司”)全部或主要部分之相關營業(含資產、負債及營業)，並以發行新股予力晶公司作為收購之對價，若有不足一股以現金支付，另通過「營業與資產收購合約」及訂定收購讓與基準日為 2019 年 5 月 1 日。

本公司另經 2019 年 5 月 7 日第七屆第七次董事會決議通過，本公司以截至收購讓與基準日 2019 年 5 月 1 日前一日之力晶公司 2019 年 4 月 30 日止之資產負債表為基準，依其讓與營業與資產之淨資產帳面價值新臺幣 22,608,182 仟元，以每股發行價格新臺幣 10 元計算，共計發行新股 2,260,818 仟股之股份予力晶公司，並訂定 2019 年 5 月 7 日為收購發行新股增資基準日。

(2)母公司力晶公司辦理減資

參照「公司法」第 168 條第二、三項及相關函釋：『公司減少資本，得以現金以外財產退還股款；其退還之財產及抵充之數額，應經股東會決議，並經該收受財產股東之同意。前項財產之價值及抵充之數額，董事會應於股東會前，送交會計師查核簽證』之規定辦理。

即力晶公司進行辦理減少資本額以現金以外財產(即本公司普通股)退還股款，業經其董事會同意提請股東會核議，並經 2020 年股東常會照案通過後，向金融監督管理委員會辦理減少資本額核准在案，並完成實收資本額變更登記，符合法定程序及相關法令之規定。

3.必要性及合理性

(1)必要性：

A.整合資源，提升產能規模

本公司經由本次組織重組，將收購力晶公司晶圓代工 12 吋 P1/2 廠及 P3 廠，加上本公司原晶圓代工 8 吋 8A 廠及 8B 廠，進而有效整合整體資源並提升生產動能。

B.市佔率之維持

配合整體未來營運發展發展之規畫，藉由產能規劃、生產製程整合之效益下，提供客戶更完整的產品線進一步提升營運績效，本公司在全球晶圓代工市佔率約 2.3%。

C.本公司組織重組之執行效益依相關財務數據說明：

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度		2018 年度(未追溯重編)	2019 年度	2020 年度	2021 上半年度
基本財務資料	流動資產	3,601,769	17,800,940	21,727,795	40,742,710
	不動產、廠房及設備	7,544,622	47,362,848	47,218,447	47,309,396
	總資產	11,918,488	73,379,654	78,914,033	98,682,264
	流動負債	3,952,307	15,862,223	17,638,074	19,417,501
	負債總額	7,021,049	43,503,273	45,696,344	48,886,979
	營業收入	7,637,449	35,897,121	45,684,615	28,573,900
	利息收入	8,800	62,543	27,977	10,792
	每股盈餘(元)	2.22	(0.94)	1.23	1.75
財務結構	負債占資產比率	58.91%	59.29%	57.91%	49.54%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	105.59%	121.44%	129.77%	167.55%

註：各期為經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；其中 2018 年度係為未追溯重編之財務資料，2021 年第二季合併財務報告之相關數字皆為經會計師查核簽證或核閱。

本公司於 2019 年 5 月完成受讓原母公司力晶科技(股)公司相關營業及淨資產，透過上述組織重組，得以有效整合集團資源。組織重組前，本公司 2018 年度營收為 7,637,449 仟元，隨著組織重組案於 2019 年 5 月完成，致年度營收增加至 35,897,121 仟元，重組後本公司擁有 3 座 12 吋廠，2 座 8 吋廠的產能資源，營收逐年穩定成長。截至 2021 上半年度，營收達 28,573,900 仟元，相較去年同期，成長 28.55%，且每股盈餘成長至 1.75 元，顯見資源整合後，生產之成長動能有效彰顯於營運成果；財務方面，因本公司之負債佔比下降且多為長期資金支應固定投資之需求，逐步穩定之財務結構，亦得顯見本公司專注於代工事業發展之決心。綜上所述，組織重組案為本公司帶來之效益已逐步顯現。

(2)合理性：

A.收購原母公司力晶公司晶圓製造業務相關營業

本次以企業併購法第 28 條進行母子間組織重組，力晶公司以晶圓代工相關營業、淨資產讓與本公司並取得本公司發行之新股；根據 IFRS 3 企業合併之定義，共同控制下個體或業務之企業合併不適用此公報，即共同控制下之合併個體性質為組織重組，應按收購讓與基準日之原資產帳面價值減去負債後之淨值作為取得股權之成本進行合併，不涉及損益及並不影響股東權益；故本次交易價格以讓與基準日以淨資產帳面價值為新臺幣 22,608,182 仟元做為計算應屬合理。

另經檢視本公司與力晶公司依晶圓製造業務相關之營業、淨資產項目，依收購讓與基準日 2019 年 5 月 1 日讓與內容說明：

(a)資產：主係包括固定資產(含廠房及設施)、存貨、應收帳款(含關係人)、使用權資產及採權益法下與晶圓製造業務相關之長期股權投資等。

(b)負債：主係包括銀行長期借款、一年內到期長期借款、應付帳款及應付費用等。

(c)所有與晶圓製造業務相關之許可證、權利證書或相關之技術，如專利、著作權及營業秘密等。

B.母公司力晶公司辦理減資

(a)換股比例

力晶公司截至 2019 年底對本公司之持股數為 2,705,196,569 股、持股比例為 87.12%，考量上市申請過程之相關持股變動包括興櫃時供券商認購、初次上市時現金增資全數對外承銷及提撥老股作為過額配售等，力晶公司完成減資換股後對本公司之持股數降為 832,792,640 股、持股比例降為 26.82%。

(b)參與減資換股作業

力晶公司進行全體股東徵詢換股意願，其中不同意以現金以外方式即本公司股票作為抵充應退還減資股款之股東，合計持有力晶公司股份 92,723,220 股，佔力晶公司總股份總數 3,170,941,181 股之 2.92%，以減資比例 60.8275286%設算，即每仟股換發 391.724714 股；不同意以現金以外方式之股東，擬抵充力晶公司股份計 56,401,226 股。

即有關本次減資所退還之財產及抵充之數額，業經徵詢收受財產之股東同意，本次力晶公司共減資新臺幣 19,288,051,550 元、銷除 1,928,805,155 股，依公司法第 168 條規定不同意之抵充應退還減資股款之股份計 56,401,226 股、同意以現金以外方式換取本公司股票計 1,872,403,929 股；即合計以現金 564,012,260 元及本公司股票抵充數額 18,724,039,290 元，作為應退還之減資股款。

(c)徵詢流程作業說明

2020 年 4 月 10 日力晶公司董事會同意以減資抵繳股款乙案，並以有權參與股東會之股東為通知對象寄發「現金以外財產退還減資股款徵詢函」，徵詢換股意願，並隨信檢附廣告回信以方便股東回覆，為避免股東對徵詢函內容理解有誤，造成股東損失，並安排人員針對勾選不同意且力晶公司原持有股數 5,000 股以上或是意思表示不明確之股東，逐一以電話確認其意願。

2020 年 6 月 24 日力晶公司股東會將減資換發徵詢結果情形報告，並通過減資換發乙案，但因通過後至實際減資換發前尚有近 3 個月時間，非法定停止過戶期間，股東皆可過戶交易，惟股東會已通過同意換發股數及換發現金之金額，因此股務代理機構以書面通知受讓人，告知所買的股份未來換股時將換現金或是股票，以避免股東間之爭議。

【承銷商說明】

1.原因及其必要性

就營業層面，可藉由受讓 12 吋晶圓廠，整合資源，提升產能規模，增加未來在晶圓代工產能擴充的彈性，藉由產能規劃、生產製程整合之效益下，提供客戶更完整的產品線進一步提升營運績效，且透過組織調整無須背負以往力晶公司向銀行紓困之歷史包袱，原因具其必要性。

2.程序之適法性

(1)收購原母公司力晶公司晶圓製造業務相關營業

2019 年 5 月進行組織重組，由該公司辦理增資作為向當時母公司力晶公司收購晶圓製造營業與相關資產之對價，其適用之法規係為企業併購法第 28 條第一項，以下就該項各款之評估說明：

企業併購法第 28 條第一項各款說明	該公司適用之評估說明
1.該子公司為公司百分之百持有。	營業讓與案係經力晶公司及該公司 2018/9/4 董事會通過，於雙方決議時，力晶公司持有該公司 100%之股權。
2.子公司以受讓之營業或財產作價發行新股予該公司。	經檢視勤業眾信聯合會計師事務所鍾會計師鳴遠出具之讓與資產及負債項目查核結果函，讓與資產項目計 47,806,519 仟元，負債項目計 25,198,337 仟元，淨資產為 22,608,182 仟元，另聯緯聯合會計師事務所呂會計師仁琦出具之價格合理性意見書，交易基準日資產帳面價值約 478 億元，負債帳面價值約 252 億元，淨資產為 226 億元，且根據該公司 2019 年 5 月 7 日董事會議事錄，該公司計發行新股 2,260,818 仟股之股份予力晶公司。
3.該公司與子公司已依一般公認會計原則編製合併財務報表。	經檢視力積電公司 2019 年度(附列 2018 年度)合併財務報告書，該公司已依規定追溯為自始取得並重編比較期(2018 年度)報表。 另檢視力晶公司 2018 及 2019 年度經會計師查核簽證之合併財務報告，該公司係為力晶公司之合併個體。雙方皆已依一般公認會計原則編製合併財務報表。

(2)母公司力晶公司辦理減資

力晶公司透過實物減資方式以所持有之力積電股票抵充應返還之減資股款，使力晶原股東得以成為力積電之股東，由於各股東可依照其持股比例參與力晶公司減資，並未損及特定股東之權益，力晶公司依公司法及相關函釋規定：「…所退還之財產及抵充之數額，須經股東會決議，並經該收受財產股東之同意。」，向全體股東進行徵詢作業，故其具程序之適法性。

3.合理性

(1)收購原母公司力晶公司晶圓製造業務相關營業

經評估聯緯聯合會計師事務所出具之價格合理性意見書，其中提及國際財務報導準則第三號(IFRS3)「企業合併」第 2 及 2A 段之說明，因該組織重組之交易性質係屬共同控制下業務之合併，故無 IFRS3 之適用，再者根據經濟部 2003 年 5 月 20 日經商字第 09200071680 號分割所涉之會計處理：「公司依企業併購法及

公司法規定，將獨立營運之一部或全部之營業讓與新設之公司，作為此新設公司發行新股予分割公司股東對價者，若分割公司股東相對持股並未改變，則仍得依財團法人中華民國會計研究發展基金會(91)基秘字第 128 號函規定辦理；因前述分割，性質係屬組織重整，其會計處理應以帳面價值為基礎，除分割公司股東權益與分割營業相關之科目應配合移轉至受讓營業之新設公司外，受讓營業之新設公司應以分割公司原資產及負債之帳面價值作為取得資產及負債之成本，並以二者淨額為基礎，面額部份作為股本，超過部份則作為資本公積……」，另參酌 95 基秘字第 114 號函及 101 基秘字第 248 號函，故使用帳面價值法尚屬適當，另根據 2019 年度經會計師查核簽證之合併財務報告，會計師查核報告中提及該合併財務報表在所有重大方面已依證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製。

綜合上述，該公司與力晶公司間收購資產組織重組之交易係屬合理，且業已按國際會計準則之相關規定辦理，經評估尚無重大異常之情事。

(2)母公司力晶公司辦理減資

該次實物減資議案，係經力晶公司董事會通過，發送徵詢函予力晶公司股東，業已充分知會原股東，並於 2020 年 6 月 24 日股東會通過。力晶公司減資前實收資本額新臺幣 31,709,415,480 元，已發行普通股總數 3,170,941,548 股，每股面額新臺幣 10 元，擬辦理減資新臺幣 19,288,051,550 元，銷除股份 1,928,805,155 股，減資比例 60.8275216%依減資暨換發基準日股東名簿記載，每仟股將銷除 608.275216 股。力晶公司參考致遠國際財務顧問股份有限公司出具之股權價值評估分析報告，決定力積電公司普通股每股價值金額為新臺幣 10 元，故以力晶公司每減少一股股份將換發一股力積電公司普通股與原股東，若原股東不同意換發者，則以每股新臺幣 10 元之現金退還減資股款。由於係採減資方式，每位股東依照原先所持有的力晶公司股票股數乘以固定的減資比例，換算可以換取力積電的股數，並未有損及單一股東之股東權益情事，故具其合理性。

【會計師說明】

1.2019 年增資收購原母公司力晶公司晶圓製造業務相關營業及淨資產

(1)程序之適法性

該公司於 2019 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要之相關營業，並由該公司發行新股予母公司力晶公司做為收購之對價。

依企業併購法第 4 條第 1 項第 4 款規定「指公司依本法、公司法、證券交易法、金融機構合併法或金融控股公司法規定取得他公司之股份、營業或財產，並以股份、現金或其他財產作為對價之行為。」，力積電公司採企業併購法第 28 條之收購方式，於收購當時即符合：

A.該公司為力晶公司百分之百持有；

B.力積電公司以受讓之營業或財產作價發行新股予力晶公司；及

C.力晶公司與力積電公司已依一般公認會計原則編製合併財務報表。

上述組織重組及收購讓與案業已分別經力晶公司及該公司董事會通過。

(2)會計處理及其合理性

2019 年 5 月 1 日營業受讓		
資產	主係應收帳款(含關係人)、存貨、不動產、廠房及設備及使用權資產	47,806,519 仟元
負債	主係銀行長期借款、一年內到期長期借款、應付帳款及應付費用。	25,198,337 仟元
股東權益	以每股發行價格新臺幣 10 元計算，總計發行新股 2,260,818,220 股普通股股份予力晶公司。	22,608,182 仟元

A.會計準則之依循

依據財團法人會計研究發展基金會所發布之問答集，有關「組織重組下追溯重編比較財務報表之疑義」及「共同控制下企業合併之會計處理疑義」所述，由於國際財務報導準則第 3 號「企業合併」對於共同控制下之企業合併並無明確規定，故仍應適用我國已發布之相關解釋函(參酌 95 基秘字第 114 號函及 101 基秘字第 248 號函)之規定，採用帳面價值法，並視為自始合併而重編前期比較財務報表。

B.查核說明

有關收購資產組織重組，茲對力晶公司 2019 年 5 月 1 日讓與營業與資產之財務資訊，依照審計準則公報第三十四號「財務資訊協議程序之執行」之規定，就受查之財務資訊執行協議程序，業已出具讓與資產負債查核結果函向原母公司力晶公司報告所發現之事實。就力晶公司截至 2019 年 5 月 1 日讓與資產項目金額計新臺幣 47,806,519 仟元及負債項目金額計新臺幣 25,198,337 仟元，經抽核各項會計科目餘額至帳冊及一定比例之原始入帳憑證等尚無不符，業經評估尚無重大異常之情事。

2.2020 年母公司力晶公司辦理減資以力積電股票抵充退還股款並規畫以力積電公司申請上市

(1)程序之適法性

依公司法第 168 條第 2 項規定：「公司減少資本，得以現金以外財產退還股款；其退還之財產及抵充之數額，應經股東會決議，並經該收受財產股東之同意。」力晶公司業已於股東會召開前依相關函釋，向全體股東進行財產抵充股款減資案之徵詢作業。並於股東會討論事項中說明收受財產之股東，係以減資暨換發基準日股東名簿記載各股東為據，且是項討論案經出席股東討論後照案通過。上述所執行之程序，並未發現有違反法令而損害股東權益之情事，然此屬認事用法範疇，應以律師專業意見為準。

力晶公司 2020 年 6 月 24 日股東會決議通過辦理減少資本額，以力晶公司持有之力積電公司股票抵充應退還之減資股款，辦理減資新臺幣 19,288,052 仟元，銷除股份 1,928,805 仟股，減資比例約為 60.83%。上述減資案業經金融監督管理委員會核准在案，減資基準日為 2020 年 8 月 16 日，業已於 2020 年 9 月 11 日完成變更登記。

(2)會計處理及其合理性

依據國際財務報導準則解釋第 17 號「分配非現金資產予業主」第 3 段所示，以國際財務報導準則第 3 號所定義之業務之分配適用國際財務報導準則解釋第

17 號之規範，因此力晶公司於減資前將業務移轉子公司力積電公司之交易應不影響適用國際財務報導準則解釋第 17 號之判斷。另參照國際財務報導準則解釋第 17 號釋例 IE3 之說明，亦參考(101)基秘字第 179 號函之附錄，由於力晶公司為公眾股東所擁有，無控制力晶公司之單一股東，亦無受合約協議共同運作而聯合控制力晶公司之一群股東。力晶公司將所持有子公司力積電公司之大部分股份等比例分配予股東，因而喪失對子公司力積電公司之控制力，故此交易屬於國際財務報導準則解釋第 17 號適用範圍，於股東會決議時認列待註銷股本並將力積電公司相關轉列待處份非流動資產及負債，後續再依國際財務報導準則第 5 號「待出售非流動資產及停業單位」衡量，前述會計處理業經評估尚無重大異常之情事。

【律師說明】

1.原因及必要性

發行公司於 2019 年收購力晶科技股份有限公司(下稱「力晶科技」)晶圓製造業務相關營業及淨資產，力晶科技於 2020 年減資並規劃由發行公司申請上市，係因力晶科技與發行公司分別擁有 3 座 12 吋廠與 2 座 8 吋廠，力晶科技除受其技術來源(美光集團)要求須對發行公司有 20%以上持股，以避免技術外流，且其於轉型前另因 DRAM 產業特性而有紓困紀錄，因此，由力晶科技之子公司即發行公司整合晶圓製造業務相關資源後申請上市，藉以提供客戶完整產品線及服務、維持其市占、減少資源重複支出，應屬妥適，而此另可避免因力晶科技之歷史包袱而影響日後籌資，故發行公司增資發行新股以收購力晶科技晶圓製造業務及淨資產、力晶科技以取得之股份抵充減資退還之股款並由發行公司申請上市，其原因並無不法亦有其必要。

2.程序之適法性

經查發行公司係於 2018 年 9 月 4 日董事會決議通過，以發行新股作為對價之方式，收購力晶科技晶圓製造業務相關營業與資產，因發行公司原係力晶科技 100%持有之子公司，並為力晶科技合併財務報表所合併之對象，而發行公司於 2019 年度編製之合併財務報表亦重編 2018 年度財務報表，與企業併購法第 28 條第 1 項規定相符。

次查力晶科技辦理減資並以其出售晶圓製造業務相關營業與資產所取得之發行公司股份抵充其應退還股款部分，力晶科技係於 2020 年 4 月 10 日董事會同意提請股東會核議，並經同年 6 月 24 日股東會通過後，向金管會辦理減資申請，經金管會核准在案後，始向經濟部辦理減資登記，而力晶科技亦於上開股東會前委請致遠國際財務顧問股份有限公司出具股權價值評估分析報告，嗣後則就以發行公司股份抵充其應退還股款部分徵詢其全部股東意見後，始辦理股份發放或退還現金，符合公司法第 168 條第 2、3 項規定。

依上所述，發行公司以發行新股作為收購力晶科技晶圓製造業務相關營業與資產之對價，力晶科技辦理減資而以發行公司股份抵充其應退還股款等程序，均係依法辦理而具適法性。

3.合理性

按企業規模發展到一定程度而進行組織重組，世所常見，我國法律規範內亦有企業併購法以供企業遵循利用。依上述，發行公司於 2019 年增資發行新股以作為收購力晶科技晶圓製造業務相關營業與淨資產，既係依法辦理，而其對價是否相當則係經會計師評估後認為合理，應認此收購案具合理性；又，力晶科技於 2020 年

辦理減資而以發行公司股份抵充其應退還股款之部分，亦係依法辦理，而其就發行公司之股權價值，則參考致遠國際財務顧問股份有限公司出具之股權價值評估分析報告後，決定以力晶科技每減少一股股份換發一股發行公司股份予其股東，如股東不同意以發行公司股份抵充，則以每股新臺幣 10 元之現金退還減資股款，故力晶科技股東之權益並未因此受有損害，應認力晶科技以股份抵充其減資退款具有合理性。

(三) 公司已於 2021 年辦理現金增資以擴充產能，亦規畫陸續投資建構銅鑼廠，請說明建廠可行性評估、重要時程進度、產品產能規劃暨資金來源及面對未來景氣波動之因應。

【公司說明】

1.銅鑼廠之資金來源規劃

(1)建廠規劃及自有資金來源

有關銅鑼廠的規劃案，最初係因力晶科技自 2013 年轉型至專業晶圓代工公司，自 2013 年至 2018 年公司已連續 5 年獲利。由於代工客戶產能需求強勁，新竹 12 吋廠區無塵室空間已飽和，只能以局部改善與去瓶頸化投資，進行技術升級與小量產能擴充，故於 2018 年與竹科管理局會勘銅鑼科學園區用地，作為主要評估建廠地點。

2019 年 5 月 1 日力晶科技與本公司完成企業重組後，本公司於 2019 年 11 月正式向科學園區管理局提出銅鑼園區租地簡報，2020 年 7 月 1 日正式起租，並命名為力積電 P5 廠，2021 年 3 月 25 日 P5 廠動土典禮完成後，建廠正式展開。

本公司分別於第八屆第二(2020/7/28)、四(2020/10/30)、五(2020/11/13)及十二(2021/7/13)次董事會取得共計 362 億元之預算金額，未來將隨著時間推進，逐步申請預算，最新規畫是以第一期月產能 3 萬片為目標，總計畫金額為新臺幣 1,076 億元。

本公司銅鑼廠(P5 廠)長期規劃是以十年期建構雙子星式的 12 吋晶圓廠(共兩座)，月產能共計 10 萬片。第一期規劃包含第一座晶圓廠、廠務棟及整個廠區(含第二座)的地下基礎建築，初步以月產能 3 萬片為目標，預估土建/廠務資金需求為新臺幣(以下同)272 億元，目前擬配置之製程技術與產品組合仍與客戶洽談協調中，初步估計設備投資金額約 804 億元，惟該金額將視未來與客戶洽談情形及市場狀況滾動式調整，並報請董事會核准後執行。

(2)外部資金來源

除自有資金外，本公司亦預計透過以下籌資方式籌措資金：

籌資方式	籌資金額 (新臺幣百萬元)	說明
增資	67,000	籌資來源不限於國內
銀行聯貸案		-
客戶預付款		與客戶協商產能預定並收取產能保證金。

2.P5 銅鑼廠擴廠預計時程

單位：新臺幣百萬元

項目		預定資金運用進度				
計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
土建/廠務	2023 年 Q1 投產	27,153	4,882	16,962	2,963	2,346
自動化/機器設備等		80,475	85	18,193	33,700	28,497
合計		107,628	4,967	35,155	36,663	30,843

3.產能規劃與生產產品

目前預定生產的產品係屬於邏輯產品，以較高階的銅製程為主力，主要為高壓邏輯製程、射頻邏輯製程與電源管理 IC 等，然實際配置的製程技術及產品組合，仍待與客戶洽談協調。

本公司預計 2023 年第一季投入生產，2023~2024 年之產能逐季上升主係受到生產之機器設備陸續裝機完成並投入生產影響所致，且本公司目前積極與銷售客戶簽訂長期供貨合約預定產能並收取產能保證金，合約中訂定銷售客戶需於合約期間向本公司購入最低購買數量，以降低本公司銅鑼廠產能閒置之風險，預計 2024 年第四季月產能 3 萬片將達到銅鑼廠之損益兩平。

4.可行性評估

(1)資金之可行性評估

本公司之銅鑼廠資金來源已透過董事會決議取得新臺幣 362 億元之預算金額，惟後續針對資本支出之自有資金需求，將提報董事會核准後執行，另本公司亦透過聯貸案增加銀行融資額度，增加資金使用彈性，且因晶圓代工產業之特性，客戶為預訂產能，預先提供資金予晶圓廠興建製程產線，故資金之來源尚具可行性。

為能加強對於資金來源之掌握度，本公司擬於近期內與各往來銀行展開洽談，徵詢其參與聯貸案之意願，基於過往長久與金融機構之往來實績，有數家大型行庫主動爭取籌組聯貸案，目前正積極展開中，籌組聯貸案應屬可行，且依據目前銅鑼廠之產能規畫及量產時程，相關財務比率估算如下表，應可達到聯貸合約之要求。

財務比率	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度
流動比率(大於 100%)	230%	358%	206%	148%	221%
負債比率(小於 200%)	85%	95%	83%	68%	54%
利息保障倍數(大於 3)	35	49	46	64	81

註：銀行要求之負債比率為負債總額/股東權益

此外，依據目前聯貸合約約定，本公司授於信案期間，每期資本支出加計非資本支出及現金股利之支出限額，不得超逾前一期期末之稅後淨利減除重大無現金流量之收入，加計折舊並扣除特別保留份額。針對限定用途於銅鑼廠資本支出之非銀行借款之資本市場籌資資金(包含但不限於發行國內外現金增資、國內外公司債等)，將另行約定不計入於支出限額公式(即不計入限額)，故支付銅鑼廠資本支出可符合聯貸合約之約定。

(2)產能規劃之可行性評估

本公司的產能隨生產設備陸續到位逐漸增加，初期鎖定客戶簽訂長期合約，

目前仍積極與銷售客戶簽訂長期供貨合約保證產能，惟根據目前本公司之訂約進度，產能之規劃尚具可行性。

本公司預計 2023 年第一季銅鑼廠開始投入量產，目前評估 2023~2025 年本公司整體毛利率將下降，主係因銅鑼廠相關不動產、廠房及設備折舊之緣故，固定成本分攤增加，致使毛利率下降，惟營業毛利方面，本公司評估 2023 年因投入生產初期，銅鑼廠之營業毛利尚為負數，但因本公司與客戶簽訂保證產能之長期合約，2024 年之銷售量將超過 3 萬片，超過損益兩平，故自 2024 年第四季本公司評估銅鑼廠將為本公司帶來正面的整體營業效益。

(3)技術之可行性評估

雖目前本公司營收占比主要係來自鋁製程技術，惟本公司第一代來自日本瑞薩 55 奈米邏輯技術及日本爾必達 25 奈米 DRAM 等之第一代相關銅製程技術，截至目前業已累積近十多年之相關量產經驗，且於現行量產中的生產線所需之後段銅製程技術都是由本公司自行開發。

邏輯銅製程亦為本公司自行開發已量產之成熟技術，本公司規畫於未來在銅鑼廠第一階段生產主要係以邏輯技術為主，包含高壓邏輯、RF、PMIC 等邏輯應用，並於 2021 年下半年開始，將陸續先於新竹 P1/2 廠試產並增加至少五個新產品 TAPEOUT，以利銅鑼廠於 2023 年底完成後，可直接快速移往銅鑼新廠進行量產，且關鍵之新設備也將於新竹 P1/2 廠配置配合試產，所以銅鑼廠將不需要重複開發新製程；高階邏輯代工製程已於 P1/2 開發完畢，目前有多家客戶正在驗證試產中，預計於 2022 年正式量產，2023 年規劃移轉至 P5 擴量。

5.面對未來景氣波動之因應

根據晶圓代工產業之特性，由客戶 consign 設備，在於約定時間內，由本公司以租金攤還模式購回，且雙方和議合約時間內的產能及價格保證之業務模式生產，相較於傳統工廠自購設備生產模式從業務銷售模式角度看來是一種雙贏。客戶預付款，但獲得穩定的成品及供貨，工廠產能獲得穩定產能利用率，可提前做好更優化之生產規劃，公司多餘的資金可更靈活運用，面對景氣循環風險較低，目前 12 吋邏輯代工客戶已有相當比例已採取此商業模式。

日前 P1/2 廠(新竹 12 吋)主要邏輯代工客戶已與本公司簽定三年產能預定合約，透過該合約，可有效鎖定新竹廠既有產能，並約定相當程度之產品價格，以確保未來三年邏輯代工產品的營收及獲利。為降低未來景氣波動對於本公司擴廠計畫之衝擊，基於現有良好的客戶關係，於銅鑼擴廠時亦與客戶深化合作，自高壓及特定邏輯產品深入 12 吋銅製程，目前正與客戶洽談長期產能預定合約，預計合約於今年底前完成。

相對主流邏輯代工廠，本公司在 12 吋銅製程為後進者，且新廠投資在成本上並沒有明顯優勢，營運策略採與客戶共同分散風險的方式，由客戶共同投資生產設備，並選定特定多量少樣的產品為第一波，迅速站上月產能 25K 經濟規模。期透過 P1/2 及 P5 長期產能預定合約雙管其下，力求能降低未來幾年內景氣波動的影響，並維持穩定獲利及持續成長。

6.總結

P5 廠長期規劃擬以 10 年期建構本公司月產能 10 萬片 12 吋晶圓之生產基地。將持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，原則以分期、分階段及本公司財務可負擔之最小風險下進行擴充廠房及產能，同時兼顧本公司穩健成長與滿足客戶產能需求。

【承銷商說明】

1.銅鑼廠之資金來源

該公司的銅鑼廠資本支出計畫資金來源：除自有資金外，其餘係對外籌措，籌措來源有：初次上市前現金增資、銀行聯貸、上市後現增及客戶預付產能保證金等，籌資工具多元，根據該公司目前的資金取得進度，經評估無重大異常之情事。

另該公司之資本支出計畫係依照專案別，逐次取得董事會通過，計畫總投入約新臺幣 1,076 億元。目前該專案已在該公司第八屆第二(2020/7/28)、四(2020/10/30)、五(2020/11/13)及十二(2021/7/13)次董事會取得共計 362 億元之預算金額，依照目前建廠進度尚屬合理。

2.銅鑼廠之規劃及重要時程

該公司需在取得董事會的預算後，方可進行採購議價及後續簽約的動作。一旦與供應商談定後，如果合約金額超過公告標準便會發布取處公告。由於該公司在 2020/10/12 補辦公開發行申報生效，該公司已分別於 2020/12/19 及 2021/5/17 發布兩則公告有關於訂購鋼構材料及委託營造廠承接租地委建專案之公告，該公司業已依規定發布取處公告。

3.銅鑼廠之產品產能規劃

目前該公司銅鑼廠預定生產的產品係屬於邏輯產品，以較高階的銅製程為主力，並以先進且高階產品為未來主要生產項目，另該公司目前係以 3 萬做為銅鑼廠之目標產能，且積極與銷售客戶簽訂長期供貨合約，以降低閒置產能之可能，且根據市場供需以分期、分階段進行擴充廠房及產能，故銅鑼廠之產品產能規劃具其合理性。

4.可行性評估

(1)資金來源及財務之可行性

依照該公司及其子公司的 Open Foundry 策略，去年已有聯發科宣布在 16.2 億元額度內買設備出租給力積電，更早也有金士頓也採用類似概念與力積電合作。為因應熱絡的晶圓代工產能需求，現在越來越多 IC 設計客戶已經能夠接受為搶產能，預先提供資金予晶圓廠興建製程產線。機器設備尚待與客戶作整體規劃才能確定資本支出。另以新建廠房及自動化工程資金需求為新臺幣 272 億元，預計申請上市時辦理現金增資發行新股 200,000,000 股，將於年底前資金到位用於支應該工程，若有不足，該公司及其子公司截至 2021 年 6 月底現金為新臺幣 228 億元，且銀行融資額度尚未動用者尚有新臺幣 125 億元，此外該公司亦規劃銅鑼廠之聯貸案，針對該公司對財務合約限制條款之評估，尚無違反限制條款之疑慮，另從該公司及其子公司最近年度及最近期分別產生 9,638,179 仟元及 8,550,401 仟元的營運活動淨現金流入，可產出穩定的現金流。綜上所述，本次擴廠計劃資金來源應具有可行性。

(2)產能規劃之可行性

該公司以漸進之方式規劃產能，並隨生產設備陸續到位逐漸增加，初期鎖定部分重要客戶簽訂長約外，該公司目前仍積極與其他銷售客戶簽訂長期供貨合約保證產能，故在產能協議下，客戶為保留該公司產能而支付之保證金，應有助於該公司產能長久穩定之規劃，其產能規劃應屬可行。

(3)土地使用權取得及興建之可行性

該公司已與科技部新竹科學園區管理局簽訂土地租賃契約，取得確切期間之

土地使用權，於 2021 年 3 月動土，經評估該公司對於擴廠計畫之土地使用權取得及廠房建造均屬可行。

(4)機器設備購置安裝及技術之可行性

由於該公司已有多座晶圓廠，且因應不同客戶需求，每年度也有既定的設備採購支出，故機器設備購入應無障礙。且依照該公司承租 8AD 廠及購買 8B 廠改建經驗，針對廠區機台擺設位置、各工作站動線安排、樓地板荷重程度、倉儲與出貨動線等已累積相當經驗，故其產線建置測試及投入量產應無困難，綜上所述，該公司在廠房之機器設備購置及安裝尚屬可行。

另該公司先前銅製程技術主要來係自日本瑞薩的 55 奈米技術與日本爾必達的 25 奈米 DRAM 技術，並已累積多年量產經驗，目前延伸的各種製程技術皆為自行開發。未來於銅鑼廠之預定生產的產品係屬於邏輯產品，以較高階的銅製程為主力，主要為高壓邏輯製程、射頻邏輯製程與電源管理 IC 等，故該公司應以具備相關同製程技術以因應擴廠所需。

綜上所述，上述之擴廠計畫之建廠可行性評估尚具合理可行。

5.面對未來景氣波動之因應評估

該公司在邏輯暨特殊應用產品之 12 吋銅製程的布局上，該公司早年自 Renesas 技轉專用，目前已能應用在自有 80/55/40nm 製程平台，但因市場需求強大，除現有 12 吋產能約 70%已與客戶高價綁定長約外，加上自有銅製程產能有限，無法充分滿足客戶需求，故進行銅鑼廠之建廠。

依據研究機構 IC Insight 統計資料顯示，該公司為全球前十大純晶圓代工廠並排名第六，該公司邏輯產品線以產品線則以 DDIC、CIS、PWMIC、MCU 及 Discrete 為主，該公司未來銅鑼擴廠計劃將與客戶深化合作，在自身擅長領域以高壓及特定邏輯產品切入擴產，故現有及其未來規劃之發展均與同業競爭對手在市場上有所區隔，故應有利於其面對全球成熟製程擴充，且該公司未來根據銅製程及鋁製程市場的供需變化，調整其公司整體產能規劃，以降低供需景氣波動可能帶來之風險。

二十六、依上市審查準則第四條第二項、第三項、或第二十八條之一第五項、第六項、或屬科技事業、文化創意事業申請股票初次上市，且委託證券承銷商辦理上市前公開銷售、並保留一定比例採洽商銷售方式辦理配售者，應增列配售名單、協議認購股數、協議配售總股數、占公開銷售總股數之比例及配售股票之集保期間與賣出限制等事項：不適用。

二十七、證券承銷商應就前款配售名單合理性、配售股數、占公開銷售總股數之比例、配售股票賣出限制、繳款資力及協議事項妥適性出具評估意見：不適用。

二十八、本國發行公司或外國發行公司前款規定委託證券承銷商辦理上市前公開銷售者，本國發行公司或外國發行人及證券承銷商應出具絕無以任何方式或名目，提供直接或間接利益予洽商銷售投資人或其指定人之聲明書。該洽商銷售投資人亦應出具絕無要求或收取發行公司或承銷商以任何方式或名目提供之直接或間接利益之聲明書：不適用。

二十九、外國發行公司有上市審查準則第二十八條之七第一項第三款或三十四條第二項第二款情事者，應將有關股東權益保護之重要事項因與註冊地國法令之強制規定牴觸，致未能增訂於公司章程或組織文件之重大差異充分揭露：不適用。

三十、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載事項：

(一)董事會運作情形

109 年 5 月 27 日股東會全面改選董監事前，董事會共計開會 2 次，董事、監察人出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率（%）	備　註
董事長	力晶科技股份有限公司	2	-	100%	代表人黃崇仁先生
副董事長	力晶科技股份有限公司	2	-	100%	代表人蔡國智先生
董事	力晶科技股份有限公司	2	-	100%	代表人陳瑞隆先生
董事	力晶科技股份有限公司	2	-	100%	代表人謝再居先生
董事	力晶科技股份有限公司	2	-	100%	代表人童貴聰先生
董事	力晶科技股份有限公司	1	-	50%	代表人謝明霖先生
董事	力晶科技股份有限公司	2	-	100%	代表人邵章榮先生
董事	力晶科技股份有限公司	2	-	100%	代表人朱憲國先生
董事	力晶科技股份有限公司	2	-	100%	代表人吳元雄先生
監察人	黃崇恆	2	-	100%	
監察人	陳錦隆	2	-	100%	

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
   (一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用。
   (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：請詳註 1。
3. 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：不適用。
4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司董事會運作均依照「董事會議事規則」辦理，以落實公司治理。

註 1：董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會居次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
第七屆第十四次	109 年 03 月 09 日	黃崇仁先生 謝再居先生 蔡國智先生 陳瑞隆先生 童貴聰先生 邵章榮先生 吳元雄先生 朱憲國先生 謝明霖先生	擬提名本公司董事及監察人候選人名單	為被提名當事人，涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	1.提名黃崇仁先生擔任董事部分，黃崇仁先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。 2.提名謝再居先生擔任董事部分，謝再居先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。 3.提名力晶科技股份有限公司代表人蔡國智先生擔任董事部分，蔡國智先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。 4.提名仁典投資股份有限公司代表人陳瑞隆先生擔任董事部分，陳瑞隆先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。 5.提名智翔投資股份有限公司代表人童貴聰先生擔任董事部分，童貴聰先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。 6.提名力元投資股份有限公司代表人邵章榮先生擔任董事部分，邵章榮先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。 7.提名智成電子股份有限公司代表人吳元雄先生擔任董事部分，吳元雄先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。

董事會屆次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
					8.提名力立企業股份有限公司代表人朱憲國先生擔任董事部分，朱憲國先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。 9.提名智特股份有限公司代表人謝明霖先生擔任董事部分，謝明霖先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。

109 年 5 月 27 日股東會全面改選董監事截至公開說明書刊印日止，董事會共計開會 16 次，董事、監察人出列席情形如下

職　稱	姓　名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率（%）	備　註
董事長	黃崇仁	16	-	100%	
董事	謝再居	16	-	100%	
董事	力晶科技股份有限公司	1	-	100%	代表人蔡國智先生，於 109 年 05 月 27 日辭任，應出席 1 次
		4	-	100%	代表人王其國先生，於 109 年 05 月 28 日改派就任。另力晶科技股份有限公司暨代表人王其國先生，於 109 年 11 月 23 日辭任，應出席 4 次
		4	-	100%	力晶科技股份有限公司暨代表人童貴聰先生，於 109 年 11 月 24 日就任，應出席 4 次
		7	-	100%	力晶科技股份有限公司暨代表人徐清祥先生，於 110 年 6 月 9 日就任，應出席 7 次
董事	仁典投資股份有限公司	1	-	50%	代表人陳瑞隆先生，於 109 年 08 月 12 日辭任，應出席 2 次
		3	-	100%	代表人顧峻先生，於 109 年 08 月 13 日改派就任，並於 109 年 11 月 24 日改派解任，應出席 3 次
		4	-	100%	代表人謝明霖先生，於 109 年 11 月 24 日改派就任，應出席 4 次
		7	-	100%	仁典投資股份有限公司暨代表人邵章榮先生，於 110 年 6 月 9 日就任，應出席 7 次
董事	智翔投資股份有限公司	5	-	100%	代表人童貴聰先生，於 109 年 11 月 23 日辭任，應出席 5 次
		4	-	100%	代表人朱憲國先生，於 109 年 11 月 24 日改派就任，應出席 4 次
董事	力元投資股份有限公司	9	-	100%	代表人邵章榮先生
董事	智成電子股份有限公司	5	-	100%	智成電子股份有限公司暨代表人吳元雄先生，於 109 年 11 月 24 日辭任，應出席 5 次
董事	力立企業股份有限公司	4	-	80%	力立企業股份有限公司暨代表人朱憲國先生，於 109 年 11 月 24 日辭任，應出席 5 次
董事	智特股份股份有限公司	5	-	100%	智特股份有限公司暨代表人謝明霖先生,於 109 年 11 月 24 日辭任，應出席 5 次
獨立董事	吳重雨	11	-	100%	於 109 年 11 月 24 日就任，應出席 11 次
獨立董事	張嘉臨	11	-	100%	於 109 年 11 月 24 日就任，應出席 11 次
獨立董事	林憲銘	11	-	100%	於 109 年 11 月 24 日就任，應出席 11 次
獨立董事	林本堅	5	1	100%	於 110 年 7 月 2 日就任，應出席 6 次
獨立董事	葉疏	6	-	100%	於 110 年 7 月 2 日就任，應出席 6 次
監察人	黃崇恆	5	-	100%	於 109 年 11 月 24 日由審計委員會替代監察人，應出席 5 次
監察人	陳錦隆	5	-	100%	於 109 年 11 月 24 日由審計委員會替代監察人，應出席 5 次
監察人	元隆投資有限公司	4	-	80%	代表人林榮生先生，於 109 年 11 月 24 日由審計委員會替代監察人，應出席 5 次

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
   (一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：經全體獨立董事核准通過。
   (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情

職　稱	姓　名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率（%）	備　註

形：請詳註 1。

3.上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：本公司於民國 110 年 03 月 09 日始董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，預計於民國 110 年度終了後依該辦法執行董事會評鑑。

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(一)本公司分別於 109 年 11 月 24 日股東臨時會補選董事(含獨立董事)及 110 年 7 月 2 日股東常會補選董事，並成立審計委員會及委任全數獨立董事擔任委員，以行使證交法、公司法及其他法令規定之職權。

(二)本公司於 109 年 11 月 24 日成立薪資報酬委員會，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，已加強董事會執行其職責。

(三)本公司訂定並業經董事會通過「內部重大資訊作業處理程序」及「防範內線交易管理辦法」。

(四)本公司網站設有「投資人專區」，提供發言人聯絡資訊，供股東諮詢公司財務、業務相關資訊。

註 1：董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會屆次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
第八屆第三次	109 年 10 月 13 日	童貴聰先生	擬提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單	為被提名當事人，涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	提名力晶科技股份有限公司代表人童貴聰先生擔任董事部分，童貴聰先生依法迴避，其餘出席董事無異議照案通過。
第八屆第六次	109 年 11 月 24 日	張嘉臨先生 吳重雨先生 林憲銘先生	1.擬訂定獨立董事酬勞 2.擬訂定「薪資報酬委員會」成員車馬費案 3.擬訂定「審計委員會」成員車馬費案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案獨立董事張嘉臨先生、獨立董事吳重雨先生及獨立董事林憲銘先生依法迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。
第八屆第十一次	110 年 7 月 2 日	葉疏先生	擬與國立臺灣大學簽訂「產學合作及學術回饋機制契約」案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案獨立董事葉疏先生依法迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。
		林本堅先生	擬與國立清華大學簽訂「產學合作及學術回饋機制契約」案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案獨立董事林本堅先生依法迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。
第八屆第十二次	110 年 7 月 13 日	力晶科技(股)公司之法人代表人徐清祥先生	本公司 110 年對力晶文化基金會捐贈案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案力晶科技(股)公司之法人代表人徐清祥先生依法迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。
第八屆第十三次	110 年 8 月 9 日	黃崇仁先生	擬解除本公司有關經理人競業禁止之限制案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案董事長黃崇仁先生依法迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。
第八屆第十四次	110 年 9 月 3 日	黃崇仁先生 謝再居先生 邵章榮	1.本公司 110 年度之經理人第三季營運績效獎金預估案	涉及自身利益關係，應依法迴避，未參與討論與表決	本案董事長黃崇仁先生、董事謝再居先生與仁典投資 (股)公司之法人代表人邵章榮先生依法迴避未參與討

董事會屆次	董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
		先生	2.本公司經理人績效評核結果 3.檢視本公司董事及經理人薪資報酬政策案 4.109 年度董監酬勞給付建議案 5.本公司 109 年度經理人之員工酬勞支領比率及金額建議案 6.本公司 110 年度之經理人第一季營運績效獎金發放案 7.擬提報經理人參與員工認股分配案 8.本公司第二次員工認股權憑證第一階段發行認股權人名冊		論及表決，其餘出席董事無異議照案通過。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1.審計委員會運作情形

自 109 年 11 月 24 日由全體獨立董事組成審計委員會至公開說明書刊印日止，審計委員會共計開會 8 次，獨立董事出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率（%）	備　註
獨立董事	吳重雨	8	-	100%	109 年 11 月 24 日新任，應出席 8 次
獨立董事	林憲銘	8	-	100%	109 年 11 月 24 日新任，應出席 8 次
獨立董事	張嘉臨	8	-	100%	109 年 11 月 24 日新任，應出席 8 次
獨立董事	林本堅	4	1	100%	110 年 07 月 02 日新任，應出席 5 次
獨立董事	葉疏	5	-	100%	110 年 07 月 02 日新任，應出席 5 次

其他應記載事項：

1.審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
109.12.18 第一屆第一次	1.擬修訂「內部控制制度」 2.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估及委任案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請第八屆第 7 次董事會決議並依照董事會決議辦理
110.03.09 第一屆第二次	1.從事衍生性商品交易情況報告 2.擬修訂「背書保證作業程序」相關條文案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	提請第八屆第 8 次董事會決議並依照董事會決議辦理

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

本公司自 109 年 11 月 24 日設置審計委員會後，稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前，將稽核報告及追蹤報告交付各審計委員，並於每季審計委員會會議上報告，雙方溝通順暢。本公司稽核主管與會計師間亦保持順暢溝通管道，並已依主管機關規定，將次一年度稽核計劃及上一年度之年度稽核計畫執行情形與年度內部控制缺失及異常事項改善情形，於完成申報作業後，一份送簽會計師存查。

2.監察人參與董事會運作情形

109 年 1 月 1 日至 109 年 5 月 27 日股東會全面改選董監事前，董事會共計開會 2 次，監察人出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出(列)席次數	實際出(列)席率(%)	備　註
監察人	黃崇恆	2	100%	
監察人	陳錦隆	2	100%	

其他應記載事項：
1. 監察人之組成及職責：監察人之組成係由股東會就有行為能力之人或法人股東代表人中選任之；本公司章程所訂監察人之職權為：(1)查核公司業務及財務狀況、(2)稽核會計簿冊及文件、(3)職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查、(4)審核預算及決算、(5)盈餘分派或虧損撥補議案之查核、(6)其他依法所賦與之職權。
2. 監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為有必要時得與員工、股東或利害關係人直接聯繫。
3. 監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形：
本公司稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前，將稽核報告及追蹤報告交付各監察人，並及時回覆監察人所垂詢事項，雙方溝通順暢。本公司稽核主管與會計師間亦保持順暢溝通管道，並已依主管機關規定，將次一年度稽核計劃及上一年度之年度稽核計畫執行情形與年度內部控制缺失及異常事項改善情形，於完成申報作業後，一份送簽會計師存查。
4. 監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、類別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

109 年 5 月 27 日股東會全面改選董監事截至 109 年 11 月 24 日(本公司設置審計委員會，替代監察人職權，董事會共計開會 5 次，監察人出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出(列)席次數	實際出(列)席率(%)	備　註
監察人	黃崇恆	5	100%	於 109 年 11 月 24 日由審計委員會替代監察人，應出席 5 次
監察人	陳錦隆	5	100%	於 109 年 11 月 24 日由審計委員會替代監察人，應出席 5 次
監察人	元隆投資有限公司	4	80%	代表人林榮生先生，於 109 年 11 月 24 日由審計委員會替代監察人，應出席 5 次

其他應記載事項：
1. 監察人之組成及職責：監察人之組成係由股東會就有行為能力之人或法人股東代表人中選任之；本公司章程所訂監察人之職權為：(1)查核公司業務及財務狀況、(2)稽核會計簿冊及文件、(3)職員執行業務之監察與違法失職情事之檢查、(4)審核預算及決算、(5)盈餘分派或虧損撥補議案之查核、(6)其他依法所賦與之職權。
2. 監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為有必要時得與員工、股東或利害關係人直接聯繫。
3. 監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形：
本公司稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前，將稽核報告及追蹤報告交付各監察人，並及時回覆監察人所垂詢事項，雙方溝通順暢。本公司稽核主管與會計師間亦保持順暢溝通管道，並已依主管機關規定，將次一年度稽核計劃及上一年度之年度稽核計畫執行情形與年度內部控制缺失及異常事項改善情形，於完成申報作業後，一份送簽會計師存查。
4. 監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、類別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則（以下簡稱公司治理實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」於 110 年 03 月 09 日第八屆第 8 次董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」，並配合公司治理實務守則強化完善的內部控制制度，提升資訊透明度，以維護股東及利害關係人的權益。	無。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		針對股東發言討論之事項，對於無爭議且可行之建議，本公司均予以接受與改善，具爭議之建議，則依議事規則採表決方式決議；且，本公司已建立發言人制度，並設有股務單位專責處理股務及股東建議或糾紛相關事宜。本公司並同時於網站上設置專門頁面，收納各項提問或建議。	無。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司隨時掌握內部人所持股權變動情形，並按時申報主要股東之持股變化情形。	無。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司已建立適當組織架構。本公司與關係企業間之業務與財務往來，已依主管機關相關規定，訂定書面規範，憑以執行。	無。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司訂有「內部重大資訊作業處理程序」及「防範內線交易管理辦法」，以防範內線交易之發生，保障投資人及維護本公司權益。	無。
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		本公司董事會成員組成，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務需求，在考慮及篩選董事候選人時，本公司基於多元化方針，衡量專業背景、學(經)歷、誠信度或相關專業資格等，目前本公司各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷、多元組成驅使本公司得以發揮經營決策及督導之機能，以期達到公司治理之理想目標。	無。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司為健全決策功能及強化管理機制，已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視實際營運需求設置其他功能性委員會。	無。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		本公司於110年03月09日第八屆第8次董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，後續將定期於年度終了後依該辦法進行董事會之績效評鑑。	無。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年定期評估會計師獨立性情形，作成書面紀錄。業於109年12月18日經審計委員會及董事會審意並通過。勤業眾信聯合會計師並出具會計師獨立聲明書。	無。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司現為興櫃公司，目前內部設有股務單位，提供董事執行業務所需之資料，協助其遵循法令，並依法辦理董事會、股東會及公司治理之相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄。	無。

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="3">運作情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則（以下簡稱公司治理實務守則）差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司有與利害關係人包括往來銀行、其他債權人、股東、員工、客戶、消費者、供應商、社區等，保持暢通之溝通管道。
本公司設有發言人制度及依法令規定將公司資訊上傳至公開資訊觀測站；對往來機構皆提供充足資訊，讓利害關係人有足夠資訊作判斷以維護權益，必要時可與公司直接進行溝通。</td><td>無。</td></tr>
<tr><td>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司業已委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為股務代理機構。</td><td>無。</td></tr>
<tr><td colspan="5">七、資訊公開</td></tr>
<tr><td>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司已於外部網頁(https://www.powerchip.com)上揭露財務業務資訊。俟公司治理制度規畫並建置完成後，亦將於網站上揭露相關資訊。</td><td>無。</td></tr>
<tr><td>(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司網站已架設中、英文網頁，並提供各相關業務聯繫之相關電子郵件信箱，及建立良好內部重大資訊處理及揭露機制，以落實發言人制度，亦有相關單位負責公司資訊蒐集並進行相關揭露。另目前本公司定期公布每月自結合併營收。</td><td>無。</td></tr>
<tr><td>(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司現為興櫃公司，適用於會計年度終了後四個月內公告並申報年度財務報告，並配合於規定期限前完成公告並申報第二季財務報告與每月份營運情形。</td><td>無。</td></tr>
<tr><td>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</td><td>✓</td><td></td><td>(一) 員工權益：本公司對員工之認股分紅、健康管理、社團休閒、貼心的福利、休假及退休制度、職涯發展，皆有相當完善的制度，相關資訊並揭露於公司網站供員工參考。
(二) 僱員關懷：本公司設置員工關懷網站，對於生涯規劃、人際關係、自我瞭解、情感交往、情緒調適...等問題，提供直接協談服務、諮商轉介服務、心理、興趣、生涯等量表施測等協談服務。
(三) 投資者關係：本公司除了於公司網站上不定期提供投資人活動訊息，對於有疑問之投資人亦開闢相關窗口直接提供服務。
(四) 供應商關係：本公司與供應商之間維持穩定良好的關係。
(五) 利害關係人之權利：本公司有與利害關係人包括往來銀行、其他債權人、股東、員工、客戶、消費者、供應商、社區等，保持暢通之溝通管道。
(六) 董事及監察人進修之情形：本公司不定期提供課程資訊予各董事、監察人，並隨時提供董事及監察人需注意之相關法規資訊，109 年度董監事進修情形如下：
<table>
<tr><th>姓　名</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr>
<tr><td rowspan="2">黃崇仁</td><td>・5G 關鍵技術與應用商機</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">謝再居</td><td>・5G 關鍵技術與應用商機</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>童貴聰</td><td>・5G 關鍵技術與應用商機</td><td>3.0</td></tr>
</table></td><td>無。</td></tr>
</table>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則（以下簡稱公司治理實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 邵章榮 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 朱憲國 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 謝明霖 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 林憲銘 ・全球十大風險解析 3.0 ・我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道 3.0 張嘉臨 ・最新投保法修正後對董監事權利義務之影響 3.0 吳重雨 ・公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析 3.0 ・新世代企業威脅管理與防範：大數據分析與公司舞弊偵防 3.0 ・董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理 3.0 ・新冠病毒對全球經濟的影響 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管—以實務案例探討為中心 3.0 ・資訊安全治理的趨勢與挑戰(下) 3.0 ・資訊安全治理的趨勢與挑戰(上) 3.0 (七) 109 年度經理人參與公司治理進修之情形如下： 姓名 課程名稱 進修時數 黃崇仁 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 謝再居 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 童貴聰 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 邵章榮 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 朱憲國 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 謝明霖 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則（以下簡稱公司治理實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 吳元雄 ・5G 關鍵技術與應用商機 3.0 ・董監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心 3.0 顧峻 ・董監事非常規交易分析與案例探討 3.0 ・智慧財產權管理與公司經營風險 3.0 (八) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司業依法訂各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 (九) 客戶政策之執行情形：本公司設有專責單位處理客戶申訴，妥善處理客戶問題，並謹守公司治理實務守則，維護消費者權益。 (十) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：不適用。				

(四)薪酬委員會運作情形

1.本公司已於 109 年 11 月 24 日由董事會決議通過並遴聘獨立董事吳重雨先生、張嘉臨先生及林憲銘先生為薪資報酬委員。

2.本委員會之職能，係以專業客觀地位就公司董事及經理人薪資報酬政及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

3.薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			選任前二年及任職期間，符合獨立性情形(註)										兼任其他公開發行公司獨立董事家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
獨立董事	吳重雨	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
獨立董事	張嘉臨			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
獨立董事	林憲銘			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

註：各董事、監察人符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓"

(1)非公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法

令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事)、監察人（監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

4.薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員會任期：第一屆任期為 109 年 11 月 24 日至 112 年 5 月 26 日，最近年度(109)及截至公開說明書刊印日止，薪資報酬委員會開會 6 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	林憲銘	6	-	100%	於 109 年 11 月 24 日就任，應出席 6 次
委員	吳重雨	6	-	100%	於 109 年 11 月 24 日就任，應出席 6 次
委員	張嘉臨	6	-	100%	於 109 年 11 月 24 日就任，應出席 6 次

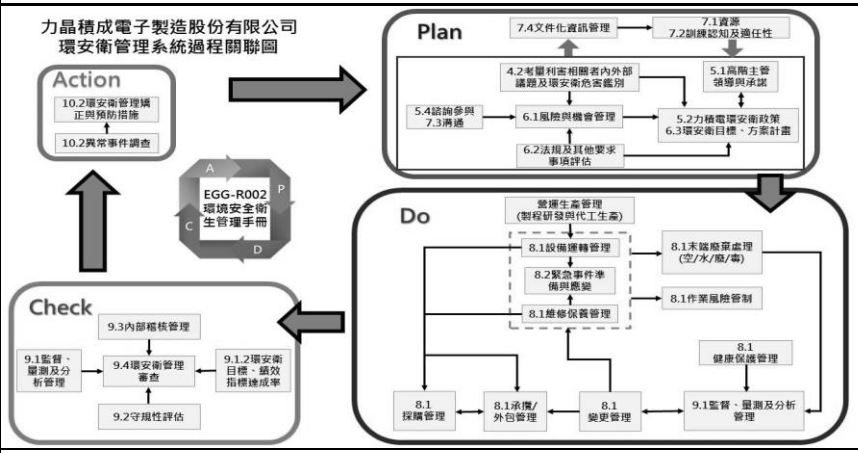
其他應記載事項：

1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。

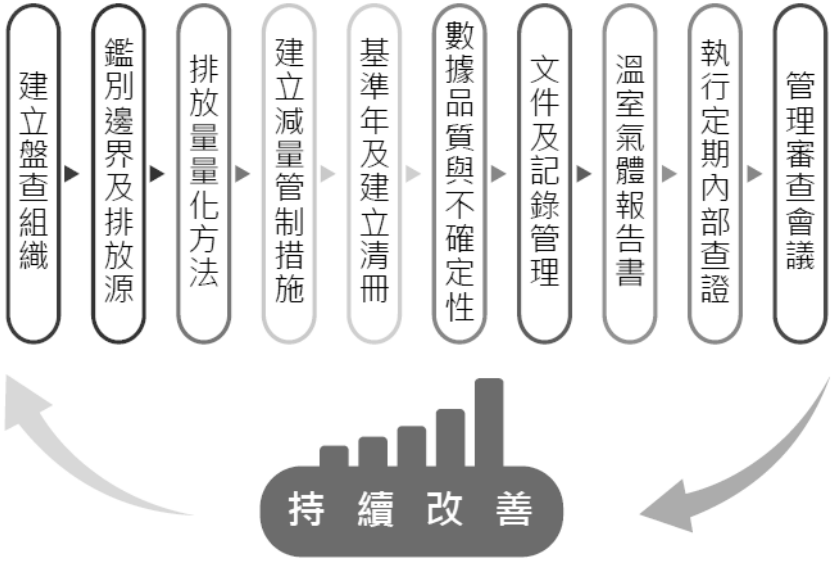
2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		為了有效整合資源、聚焦晶圓代工事業，本公司已於108年5月完成企業架構調整，收購原母公司力晶科技(股)公司旗下三座12吋晶圓廠及相關營業、淨資產。整併後擁有三座12吋廠、兩座8吋廠及逾7000名員工，本公司深知規模越大對產業、社會的影響也越深，除了平衡利益關係人、社會、企業三者的關係，更希望以自身營運經驗建立永續發展典範，參採聯合國永續發展目標（SDGs)，融入社會創造分享共榮的良性循環。本公司重視承諾，並持續關注各項新議題以及趨勢的演變，來調整對社會責任之承諾，使其更加完整地涵蓋所有面向，並依此作為落實企業社會責任的目標和方向。每年除了定期完成企業社會責任報告書，也將成果公告於公司網頁，以調和與各利害關係人的關係。	無。
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	✓		本公司根據中華民國公司法、證券交易法以及其他相關法令，訂定公司章程及公司各項規章辦法，並在遵守國家法令與公司設立各項規章制度之原則下，制定公司治理架構並執行運作。 在推動企業社會責任的工作上，以風險管理處為目前報告資訊彙整兼職單位，然實務工作內容均已落實在有關部門中，除了傳統的財務指標外，整合社會正義性、環境永續性、財務績效等倫理性指標，穩定利潤分配的持續性與社會貢獻程度，使各項推行工作及利害相關者關心議題也都能按部就班的持續進行。	無。
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		身為地球村的一份子及企業應盡的社會責任，本公司致力於環境保護、職業安全及健康促進之提昇，積極進行環安衛相關管理系統之建置與執行；如ISO-14001、ISO-45001、CNS-45001(TOSHMS)、ISO-50001、溫室氣體查證、企業責任報告書等，以確保公司內之環境管理及職業安全衛生相關管理活動皆符合國際趨勢及潮流。 本公司的環安衛管理系統運作，依循總經理頒佈之環安衛政策，依據現有組織架構規劃環安衛管理推動工作；在每年年初依企業社會責任重大議題篩選程序與結果，確定與環安衛議題相關之重大風險衝擊方向，經總經理核定相關環安衛議題之年度策略目標，並由各部門依其風險與機會評估結果據以研擬具體可行之工作目標加以執行，再按季執行進度追蹤，並且透過每半年進行之內部環安衛稽核，對整體系統運作執行狀況進行檢查與矯正，且將稽核結果及系統執行成效提報予環安衛管理委員審查，共同進行檢討及修正，以達到持續改善之目的。	無。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
				
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		「因應氣候變遷減緩與調適及永續資源使用之議題，執行節能減碳的活動，並促進資源有效使用」是本公司環安衛政策的重要環境準則。本公司致力於各項廢棄物的減量與再利用，提高資源有效再利用率，善用能資源、保護地球。	無。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		台灣近年常發生缺電或缺水情形，如不積極管理，可能會影響生產，甚至未來將面臨相關法規上的風險，因此配合國家相關法令與國際節能減碳趨勢，努力減少能源耗用，提升水回收率及製程用水效率，為本公司降低氣候變遷造成衝擊之管理目標；目前本公司設有溫室氣體盤查及減量管理小組，監控溫室氣體排放情形，除已導入ISO50001、ISO14001、ISO14064-1及ISO14067等國際管理系統，亦同步考量環保主管機關相關規定與利害相關者要求，每年制定節電節水措施及設定目標，各項目標訂定及成果說明如下： ● 配合經濟部「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫」規定，實施各項節電方案，如檢視並改善降低生產單位產品用電量、老舊設備規劃汰舊換新及再生能源開發等措施，本公司於108及109年皆達成年度節能1%。 ● 持續推進半導體高階製程技術，為客戶生產先進、節能及環保的產品，為地球永續發展盡一份心力。。 ● 因應氣候變遷減緩與調適，設立溫室氣體盤查與減量管理小組，每年統計溫室氣體排放數據，本公司於108及109年皆達成年度減碳1%。 ● 持續透過技術改善與設備投資，成為園區第一家承諾製程用水回收率達	無。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			85%以上的半導體廠，本公司於108及109年皆達成製程回收率85%以上。	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		在廢棄物減量及資源化方面，本公司持續推動廢溶劑清查專案、IPA濃縮再利用、落實廢棄物有效分類並節省水資源等措施，不斷監控驗證汰換機台及管路閥件以達降低整體廢溶劑的產出量；另也導入生命週期循環的管制理念，持之以恆的提升廢棄物再利用之價值，與廠商合作進行回收再利用可行性評估，以確保後端產品去處無虞，以109年與108年數據相較，單位面積晶圓廢棄物產出量約減少10%以上，109年整體廢棄物再利用率達85%以上之目標亦順利達標(約達87%)，以此長期努力成果，本公司8A廠也榮獲「109年度廢棄物減量及循環經濟績優企業評鑑活動」特優獎之肯定。 在水資源管理績效方面，本公司為園區第一家承諾製程用水回收率達85%以上的半導體廠，因應氣候變遷減緩與調適，109年推動節水減排政策以提升製程回收率及降低全廠排放率作為執行目標，主要以提升循環水再利用率、製程廢水確實分流及評估減少機台用水量及排放量做為主軸；109年與108年相較單位面積晶圓用水量約減少17%，其中全公司製程水回收率高達88%以上(每滴水使用平均約可達3次)，全公司排放率低於67%；自建廠以來皆秉持優良之節水傳統，透過持續技術改善與設備投資，使節水工作成為我們的使命。且因應氨氮削減要求趨勢，本公司12吋廠因廢水量較具規模，故堅持選用安全性高、零廢棄物、高建置成本之觸媒法做為削減氨氮之環保設施，除可降低水體氨氮負荷外，更達到不產出廢水處理衍生污泥，減少對環境二次傷害之成效，並配合科學園區管理局宣導推廣計畫，將此觀念與成果對其他民眾與團體進行分享與說明。本公司P1/2 廠於108年參加園區節水績優廠商評選並榮獲節水績優廠商獎，除配合舉辦年度節水績優廠商現場觀摩活動，與同業分享廠內節水經驗，更在同年12月與新加坡National Water Agency 進行回收水經驗交流會，分享本公司回收水分流/ 處理/ 再利用經驗。 為能有效執行節能減碳及溫室氣體減量策略，本公司制定了「溫室氣體排放減量管理辦法」及「能源管理手冊」來強化公司內部管理，並透過訂定能源政策及環安衛政策作為節能減碳推行目標。 在溫室氣體減量目標方面，本公司設有溫室氣體盤查及減量管理小組，小組成員由公司內部涉及溫室氣體產生或排放相關之設備/設施運轉、製程生產以及人為運作活動行為之相關部門管理人員所組成，管理人員針對與溫室氣體有關之資訊，定期進行蒐集；其次依據ISO14064-1規範進行溫室氣體排放量	無。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			盤查驗證作業，包括針對各廠內製程排放、揮發性有機物(VOCs)燃燒排放、汽柴油使用、天然氣使用 …等等直接排放源，以及外購電力間接排放源等進行盤查及內、外部查核驗證作業，109年因應氣候變遷減緩與調適，推動節能/減碳方案，訂定削減溫室氣體1%，各部門並擬定相關溫室氣體減量措施與削減計劃，按照時程進行持續減量。目前本公司已完成89~108年溫室氣體排放量盤查作業，且均獲得第三方認證機構認證並取得認證聲明書，亦依法令要求自103年開始進行盤查資料登錄作業，108年度本公司溫室氣體排放總量相較107年降低2.4%，109年度溫室氣體排放資訊，則規劃於110年7月前完成第三方查證後對外揭露。而依據環保署先期減量暨抵換專案推動原則，本公司以優於公告排放強度的減量績效，取得行政院環境保護署核發減量額度共計501,252噸CO2e，是少數獲得環保署認可自我先期減量具成效的半導體事業單位。  在能源管理減碳目標方面，自104年起12吋廠更進一步推動ISO50001管理系統建置，分析本公司能源使用現況與建立能源基線資料，藉由鑑別重大能源使用設備及排序，持續尋找改善能源績效之機會，並擬訂適當的能源績效指	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			標，使得平均年節電率皆達百分之一以上。另為持續配合政府政策，更積極參與經濟部工業局電子業工作小組定期會議，共同討論減量潛力及效能標準獎勵辦法，找出氣候變遷對公司營運所帶來的風險與機會，未來五年(中華民國104年至113年)也將持續響應「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」平均年節電率應達百分之一以上之目標前進。 未來將依循總經理頒佈之能源政策，循序漸進將能源管理系統導入8吋廠，以加強設備能源管理並優化能源使用效率，促使企業永續經營。	
四、社會議題				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司依法為同仁加入勞健保並提撥退休金，各項規章制度皆符合勞動法規規範，亦制定勞工及人權政策，以健全的人事管理制度，保障員工合法權益。	無。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司會依營運狀況適時發放激勵獎金，另有三節禮卷、生日禮卷、結婚賀禮及生育補助、喪葬補助、子女獎助學金。	無。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司為努力減低事業活動、產品及服務對環安衛及健康影響等事項之風險衝擊及系統地、持續地推行環境安全衛生管理；並依PDCA原則運作符合主動積極改進環安衛管理系統績效，預防職業傷害與健康影響、污染預防及環境保護的精神。彙整本公司環安衛管理方式其特色如下： (1)環安衛管理系統之整合 本公司於108年展開ISO45001轉版系列工作，並於109年順利完成第三方驗證，環安衛管理系統運作特色主要整合ISO14001、ISO45001及TOSHMS等管理系統整體運作，持續提昇公司在環境保護、員工健康與設備安全等面向的有效管理，本公司將以長期以系統化管理風險、持續改善為營運基準，除了持續通過ISO14001及ISO45001之定期稽核、勞動部職業安全衛生署之CNS45001驗證核可，亦透過PDCA的邏輯性思考及措施推動，展現企業在全員參與、持續改善、重視員工安全與健康的精神。 (2)環安衛相關電子化管理系統之建置與管理 為求訊息傳遞迅速、增加運作管理效能，透過環安衛相關電子化管理系統建置與管理，將已上線的管理系統如：環安衛風險評估、環安衛法令管理、環安衛教育訓練計劃及法定證照、化學品安全資訊、承攬商管理、門禁刷卡、特殊作業許可單、防護具管理、異常事件調查、e-Auditing、疏散點名及員工健康管理、E-Learning、MyCKM教學等系統進行資訊分享與串聯，透過現場同仁與線上查詢系統雙向互動的機制，有效提昇人員的安全認知	無。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			程度。 (3)危害鑑別與風險評估 建立系統化之危害鑑別與風險評估方法，同時運用HAZOP、BCP、SWOT等評估技術外，亦推行作業活動本質風險與控制後風險並列考量模式且每年檢視執行狀態，有效呈現公司面臨的環安衛風險與機會、各部門作業風險之管制措施執行成效。 彙整109年度各部門全面性風險評估定期檢視結果，共有42,225項環安衛作業風險，共有14項風險需衝擊評估案件持續進行評估與管制；另為能充份考量利害關係者重視及關注之議題，在企業社會責任報告撰寫過程中亦藉由問卷調查、SWOT及風險評估等方式找出6項不可接受風險，均已列為110年環安衛年度目標進行改善評估及追蹤，持續降低環保、工安及衛生面向之營運風險。 (4)完整防護管理機制建立 為保障公司權益及同仁安全健康，針對不同危害差異建制完整防護管理，包括設備機台安全防護、環境監控防護與人員操作防護，從機台購入階段即依據SEMI S2、NFPA、FM等標準，確認機台本質安全之設計理念，並配合機台到廠安裝以及最終拆除時程，對不同設置階段可能產生之危害，由相關部門人員逐項進行確認，輔以環境氣體偵測、漏液偵測、消防偵測、製程參數偵測等系統監控，務使作業環境之可能風險有效獲得掌控。另外公司亦制訂各項職業衛生危害預防計畫，保障本公司工作者免於職業病之威脅；以呼吸防護計畫為例，除保障人員使用個人防護器具基本權益外，更是透過生理評估、呼吸防護具佩戴密合度測試、部門代表與線上查詢系統雙向的互動機制，有效提昇人員正確使用的認知程度與使用意願。 (5)異常事件追蹤管理 為有效防止事故之再發生，針對異常狀況、危害辨識、虛驚事故進行改善及執行追蹤，設計異常狀況矯正追蹤系統，可清楚呈現各項改善措施執行進度與成效。 (6)諮詢與溝通 透過佈告欄、電子看板、網路公告、安全衛生環保通訊、提案立案、夥伴的話、利害關係人問卷調查、推動零工傷活動、協議組織會議及環安衛代表定期溝通會議等多重管道進行意見反應、諮詢溝通與教育宣導，達成雙向意見交流之良好效果。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(7)員工健康管理 廠內設有專任護理師，提供專業之健康保健、舉辦健康促進活動及緊急救護處理等服務，讓同仁的健康零負擔。為提供員工即時、快速、有效的醫療服務，減少往返醫院掛號、等候耗費的時間和金錢，亦設公司專屬診所提供門診服務、健康諮詢、預防接種等健康管理服務，服務對象擴及同仁眷屬、關係企業員工及承攬商，另有臨廠服務之職業醫學科專科醫師提供健康教育、衛生指導之策劃並協助員工選配適當工作。而電子化之健康管理系統則提供員工隨時查閱個人歷年健檢報告，以掌控自己的健康狀況，並可同時查詢掛號資訊、報名健康促進活動及健康問題諮詢等，多元化及全方位之資訊化健康服務，以強化同仁自主健康管理之能力，進而達到預防保健的功能。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		為使員工與公司同步成長，本公司教育訓練係以公司經營理念、長期營運策略及人才發展策略建置完整訓練計畫。透過內外部訓練讓員工增進工作技能，對環境變動快速適應，並提升工作績效，改善產品及服務品質，創造員工個人與組織整體競爭力，使員工職涯發展與企業經營發展相輔相成。	無。
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	✓		本公司生產之產品均符合IC產品可靠度測試的商業標準與國際ISO認證(如ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949)及國際綠能標準(符合歐盟RoHS法規及SONY Green Policy規範)，以提供客戶品質無虞之產品為宗旨。 本公司對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法；為降低員工、訪客和客戶的健康和安全風險，亦通過OHSAS 18001認證。同時對產品與服務亦提供標準化且有效之申訴程序，並與客戶於契約中明訂責任歸屬與相關規定。如遇相關問題，可直接與本公司網站所提供之業務人員聯繫，將有客服單位及利害關係人專區保護消費者權益政策及提供申訴管道。	無。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司制定供應商行為準則聲明，要求供應商於勞工、健康與安全、環境、商業道德及管理體系等各方面之商業行為確實符合本準則，並完全遵守經營所在國家/地區的法律和法規。同時，本公司會定期進行查核，查核結果亦為公司決策的重要因素之一。	無。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司聆聽並回應利害關係人所關注之議題，在企業社會責任報告書編製過程中，鑑別利害關係人所關注之永續議題，作為報告書資訊揭露的參考基礎，以利與各利害關係人進行有效溝通。在公司外部網頁(https://www.powerchip.com)亦已規劃有企業社會責任專欄，並放置「企業社	無。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			會責任報告書」完整內容可供各界參考，而對於各利害相關者所提及的資訊需求，也可藉由各通訊、電子管道或公司拜訪等得到充分的溝通與了解。為增加報告書之公正性，108年度報告書已委託第三方驗證機構-英國標準協會(BSI)，依據GRI準則及AA1000 AS(Assurance Standard)保證標準(2008)及其107年附錄之第二類之高度保證等級方式查證,經查證後本報告書符合上述架構及保證標準等級，並已取得保證聲明書。 本公司針對各項環安衛管理、員工健康管理及勞資關係與員工發展均落實執行，內部均有管理報告及會議進行溝通與諮詢；而公司外部網頁(https://www.powerchip.com) 亦有揭露公司主要環安衛管理方針內容及放置企業社會責任報告書資訊，並於報告書內容逐步檢討納入相關環安衛目標及執行績效，公開讓大眾取得參考。	

六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於110年03月09日第八屆第8次董事會決議通過訂定「企業社會責任實務守則」，其運作情形皆與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」內所規範之精神及原則一致。

七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：

環安衛成果：

身為地球村的一份子及企業應盡的社會責任，本公司致力於環境保護、職業安全及健康促進之提昇，積極進行環安衛相關管理系統之建置與執行；如ISO-14001、ISO-45001、CNS-45001(TOSHMS)、ISO-50001、溫室氣體查證、企業責任報告書等，以確保公司內之環境管理及職業安全衛生相關管理活動皆符合國際趨勢及潮流。

- 配合經濟部「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫」規定，實施各項節電方案，如檢視並改善降低生產單位產品用電量、老舊設備規劃汰舊換新及再生能源開發等措施，本公司於108及109年皆達成年度節能1%。
- 持續推進半導體高階製程技術，為客戶生產先進、節能及環保的產品，為地球永續發展盡一份心力。
- 因應氣候變遷減緩與調適，設立溫室氣體盤查與減量管理小組，每年統計溫室氣體排放數據，本公司於108及109年皆達成年度減碳1%。
- 持續透過技術改善與設備投資，成為園區第一家承諾製程用水回收率達85%以上的半導體廠，本公司於108及109年皆達成製程回收率85%以上。
- 109年與108年相較單位面積晶圓用水量約減少17%，其中全公司製程水回收率高達88%以上(每滴水使用平均約可達3次)，全公司排放率低於67%。

本公司將持續關注各項新議題以及趨勢的演變，並依此作為落實企業社會責任的目標和方向，與社會和環境共榮共存，以自身營運經驗建立永續發展典範。

公益活動：

本公司秉持愛與關懷，透過實際參與及服務，對社區、文教機構和弱勢團體提供協助，盼能為社會盡一份心力，善盡企業公民的責任，陶養社會和諧良善、彼此扶持、分享共好的風氣。

時間	活動內容
109 年 1 月	【吃好米・做好事・送好鞋】頤禾園-109年認購竹東軟橋在地母親の有機米，由農園捐出「穀利」做為購鞋基金。本次共募得NT$283,020

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則（以下簡稱企業社會責任實務守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
	元，捐出共計約98雙鞋。 - 新竹縣尖石鄉 方濟幼兒園-約52雙。 - 新竹縣五峰鄉 聖心幼稚園-約28雙。 - 新竹縣五峰鄉 桃山國小幼兒園-約18雙。			
109 年 8 月	創世&伊甸基金會【振興券做愛心】-共募得NT$168,800元。由同仁捐出部分三倍券給創世基金會，共可認助植物人一個半月的照顧費用(新竹院內目前安養63位植物人)，除善盡企業社會責任外，也讓弱勢植物人及家庭感受到社會的溫暖。			
109 年 9 月	月圓人團圓【尖石偏鄉送月餅】：捐贈愛心月餅至尖石山區：尖石國小(約30份)、教會捐贈(嘉樂24份 / 新樂24份；其餘約67份由神父後山發放)。			
109 年 12 月	【袋受飢兒過好年】世界和平會-共募得NT$683,300元，協助新竹分會在寒冬中幫助500位貧童。			
八、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 公司針對各項環安衛管理、員工健康管理及勞資關係與員工發展均落實執行，內部均有管理報告及會議進行溝通與諮詢；而公司外部網頁(https://www.powerchip.com) 亦有揭露公司主要環安衛管理方針內容及放置企業社會責任報告書資訊，並於報告書內容逐步檢討納入相關環安衛目標及執行績效，公開讓大眾取得參考。				

(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則（以下簡稱誠信經營守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司於110年03月09日第八屆第8次董事會決議通過訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，作為本公司董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾。公司並訂定各項內部辦法以確保誠信經營與法令遵循之落實。	無。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少	✓		本公司「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，內容已訂定防範不誠信行為之相關作業程序，並積極落實。	無。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則（以下簡稱誠信經營守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？				
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		本公司「誠信經營作業程序及行為指南」針對較高不誠信形為風險之營業活動採行必要之防範措施，另本公司之「董事及經理人行為準則」與「員工行為準則」中，對於董事、經理人與員工之行為和懲戒等，均有明確之規範，並定期檢討修正前揭方案。	無。
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司訂定之「敬業規範」引導同仁執行職務時，恪守與業務相關之上下游利害關係人間之互動，並於Invoice中明確規範員工及廠商彼此間應遵守之誠信原則。	無。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司由敬業促進委員會負責推動誠信經營作業程序及行為指南知制定及執行，並將相關情事、其處理方式及後續檢討改善措施，未來將向董事會報告。	無。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司制定「誠信經營作業程序及行為指南」均有訂明規範，業已防止利益衝突政策。 另本公司同仁於執行業務時若有涉及不法情事，內外部人士均得以匿名或具名方式檢舉，並提供適當陳述管道。	無。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司訂定健全之「會計制度」及「內部控制制度」，並隨時檢討，以確保該制度之設計及執行持續有效。內部稽核人員依照年度稽核查核計畫定期查核作成稽核報告，提交審計委員會同意後，並提報董事會決議通過。	無。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司之董事、監察人與經理人參與外部機構之進行課程，公司新進員工於教育訓練時即強調誠信經營之企業文化及其重要性與公司規範。 本公司目前尚未定期舉辦，未來視需要執行。	無。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則（以下簡稱誠信經營守則）差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司制定「公司道德行為準則」，並建立便利檢舉管道，具遇有檢舉事項，將由董事會或董事會所指定之專責單位調查之。目前並無違反誠信經營或不合法情事發生。	無。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司設有多元檢舉及申訴管道，受理檢舉事項其作業以保密及公平為原則，依檢舉事項處理程序辦理。	無。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		檢舉人身分受保護為原則，不因檢舉而遭受不當之處置。	無。
四、加強資訊揭露				
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司於110年03月09日第八屆第8次董事會決議通過訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及指南等辦法，未來將陸續揭露於本公司網站，並依法於公開資訊觀測站即時公告及更新相關資訊。	無。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於110年03月09日第八屆第8次董事會決議通過訂定「誠信經營守則」其運作情形與所訂守則內容皆與「上市櫃公司誠信經營守則」內所規範之容無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。				

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：可至本公司網站https://www.powerchip.com查詢。

(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無此情事。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

三十一、發行公司辦理公司治理資訊揭露之情形：

初次申請有價證券上市公司之公司治理相關資訊揭露情形

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
一、公司治理架構及規則					
（一）公司是否建置公司治理制度並涵蓋主要治理原則	是	本公司已訂定「公司治理實務守則」。	-	-	-
（二）公司是否建立完備之內部控制制度並有效執行	是	本公司已建立有效之內部控制制度，並有稽核人員依據董事會通過之稽核計劃執行查核工作。	-	-	-
二、公司股權結構及股東權益					
（一）公司是否訂有股東會議事規則	是	本公司已訂定「股東會議事規則」，並依規定召開股東會等相關事宜。	-	-	-
（二）公司是否設有專責人員處理股東建議或糾紛等問題	是	本公司設有發言人、代理發言人各一名，以及時處理股東之建議、疑義或糾紛等問題。	-	-	-
（三）公司是否隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單	是	本公司依據股務代理機構辦理停止過戶時所提供之股東名冊，確實並隨時掌握對於主要股東、董事及經理人持股情形。另對於內部人之持股變動情形，業已依法令規定進行申報。	-	-	-
（四）公司是否揭露主要股東有關質押、增加或減少公司股份等重要事項	是	本公司業已依規定揭露主要股東有關之質押、增加或減少公司股份等重要事項。	-	-	-

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
（五）公司與關係企業是否建立適當風險控管機制及防火牆	是	本公司業已制定「關係企業相互間財務業務相開作業規」、「子公司監理作業辦法」及「關係人交易管理辦法」等作業程序，以規範本公司與關係企業間之權責，並確實執行風險評估及建立適當風險控管機制及防火牆措施。	-	-	-
三、董事會結構及獨立性					
（一）公司是否設置二席以上獨立董事	是	本公司業已依規定設置五席獨立董事。	-	-	-
（二）公司董事會是否設審計委員會	是	本公司業已於109年11月24日完成設置設審計委員會，並由獨立董事擔任委員。	-	-	-
（三）公司董事長、總經理是否由不同人擔任，或是否無配偶或一等親之關係	是	本公司之董事長、總經理係由不同人擔任，且無配偶或一等親之關係。	-	-	-
（四）董事對於有利害關係議案之迴避是否確實執行	是	本公司之董事對於有利害關係議案已確實執行迴避。	-	-	-
四、董事會及經理人之職責					
（一）公司是否訂有董事會議事規則	是	本公司已訂定「董事會議事規則」，並按規定辦理相關事宜。	-	-	-
（二）公司是否訂定各專門委員會行使職權規章	是	本公司設有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，並對前揭委員會制定相關組織規則，且皆已依規定進行辦理。	-	-	-
（三）公司董事會是否定期評估簽證會計師之獨立性	是	本公司董事會係依法令規定定期評估簽證會計師之獨立性。	-	-	-

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
（四）公司是否有為董事購買責任保險	是	本公司業已為董事購買責任保險。	-	-	-
（五）公司是否訂有董事進修制度	是	本公司業已制定「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」等規範董事進修制度，且本公司亦不定期舉辦董事之專業知識進修課程，以符合法令規定之進修時數。	-	-	-
（六）公司是否訂定風險管理政策及風險衡量標準並落實執行	是	本公司為執行風險控管，訂定相關辦法，包含「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」等辦法，對公司財務及業務所面臨之風險，明訂適當風險限額及監控機制，內部稽核人員亦持續對政策之遵循進行覆核，以確認相關作業已依規定辦理。	-	-	-
五、監察人之組成、職責及獨立性					
（一）公司是否設置一席以上獨立監察人	不適用	本公司以審計委員會取代監察人職權，故不適用。	-	-	-
（二）監察人與公司之員工、股東及利害關係人是否建立溝通管道	不適用	本公司以審計委員會取代監察人職權，故不適用。	-	-	-
（三）公司是否成立監察人會或訂定議事規則	不適用	本公司以審計委員會取代監察人職權，故不適用。	-	-	-
（四）公司是否有為監察人購買責任保險	不適用	本公司以審計委員會取代監察人職權，故不適用。	-	-	-
（五）公司是否訂有監察人進修制度	不適用	本公司以審計委員會取代監察人職權，故不適用。	-	-	-
六、利害關係人之權利及關係					

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
（一）公司是否建立與利害關係人之溝通管道	是	本公司網站(http://www.powerchip.com/)已建立利害關係人之溝通方式，包含電話及電子信箱等聯絡管理，以方便利害關係人能直接與本公司聯絡，並可陳相關單位進行處理。	-	-	-
（二）公司是否重視公司之社會責任	是	本公司進行各項商業活動時，均秉持誠信原則，以維護利害關係人之權益，並持續強公司治理、重視環境保護，善盡企業社會責任。相關企業社會責任之執行亦揭露於公司網站。	-	-	-
（三）公司是否訂定保護消費者或客戶之政策並定期考核其執行情形	是	本公司訂定客戶服務作業以規範客戶投訴管道及處理程序。	-	-	-
七、資訊公開					
（一）公司是否指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作	是	本公司係已指派專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。	-	-	-
（二）公司是否建立發言人制度	是	本公司設有發言人及代理發言人，以妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。	-	-	-
（三）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊	是	本公司業已於公司網站揭露財務業務及公司治理資訊。	-	-	-
八、其他應揭露事項：無。					

陸、重要決議、公司章程及相關法規

一、重要決議應記載與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表)

(一)與本次發行有關之決議文：請參閱本公開說明書附件十四。

(二)盈餘分配表：請參閱本公開說明書附件十四。

(三)公司章程及新舊條文對照表：請參閱本公開說明書附件十五。

二、未來股利發放政策

依本公司章程規定，本公司每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後之。

本公司公開發行後分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告於股東會。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中現金股利於股利總額之 10%~100%，股票股利於股利總額之 0%~90%。

三、未來辦理增資計畫及其對獲利能力稀釋作用之影響

未來現金增資發行價格之訂定，主要係考量產業前景、公司競爭利基、未來營運狀況及發行市場環境等因素後，與證券承銷商協商後共同訂定承銷價格，而實際發行價格，則待主管機關核准之，再由本公司與證券承銷商視當時市場之狀況及最近期之營運情形，並經董事會議定之。本公司目前處於成長階段，對未來營收及獲利狀況尚屬可期，故未來本公司辦理現金增資對每股獲利能力之稀釋程度應尚屬有限。

【附件一】

一〇八年度合併財務報告暨會計師查核報告

股票代碼：6770

力晶積成電子製造股份有限公司
及子公司

合併財務報告暨會計師查核報告

民國 108 及 107 年度

地址：新竹科學工業園區新竹市力行一路18號

電話：(03)579-5000

§目　　錄§

項目	頁次	財務報告附註編號
一、封　　面	1	-
二、目　　錄	2	-
三、關係企業合併財務報告聲明書	3	-
四、會計師查核報告	4～7	-
五、合併資產負債表	8	-
六、合併綜合損益表	9～10	-
七、合併權益變動表	11	-
八、合併現金流量表	12～13	-
九、合併財務報告附註		
(一) 公司沿革	14	一
(二) 通過財務報告之日期及程序	14	二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	14～18	三
(四) 重大會計政策之彙總說明	18～30	四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	30～31	五
(六) 重要會計科目之說明	31～62	六～二六
(七) 關係人交易	63～67	二七
(八) 質抵押之資產	68	二八
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	68～69	二九
(十) 其　　他	69～70	三十
(十一) 重大之災害損失	-	-
(十二) 重大之期後事項	-	-
(十三) 具重大影響之外幣資產及負債資訊	70	三一
(十四) 附註揭露事項		
1. 重大交易事項相關資訊	71、73～75	三二
2. 轉投資事業相關資訊	71、73～75	三二
3. 大陸投資資訊	71	三二
(十五) 部門資訊	72	三三

關係企業合併財務報告聲明書

本公司108年度（自108年1月1日至108年12月31日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：力晶積成電子製造股份有限公司

董事長：力晶科技股份有限公司

代表人：黃崇仁

中　華　民　國　109　年　3　月　9　日

會計師查核報告

力晶積成電子製造股份有限公司　公鑒：

查核意見

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與力晶積成電子製造股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

如合併財務報告附註十所述，列入力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司合併財務報表中之部分子公司，民國 107 年度之財務報表係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關民國 107 年 12 月 31 日前述子公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，該等子公司其民國 107 年之資產總額為新台幣 10,982 仟元，占合併資產總額之 0.02%；負債總額為新台幣 2,077 仟元，占合併負債總額為 0.01%；民國 107 年度綜合損益總額為綜合損益新台幣(91,982)仟元，占合併綜合損益總額之(1.33)%。

力晶積成電子製造股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估力晶積成電子製造股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算力晶積成電子製造股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對力晶積成電子製造股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使力晶積成電子製造股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致力晶積成電子製造股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於力晶積成電子製造股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成力晶積成電子製造股份有限公司及子公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

強調事項

如合併財務報告附註一、十及三十所述，力晶積成電子製造股份有限公司於民國 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶科技股份有限公司全部或主要之相關營業，並由力晶積成電子製造股份有限公司發行新股予母公司力晶科技股份有限公司做為收購之對價，及由母公司力晶科技股份有限公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.讓與力晶積成電子製造股份有限公司；與民國 108 年 4 月 1 日由力晶積成電子製造股份有限公司將持股 100%之富碩投資股份有限公司及 Sprout International Limited 全數出售予母公司力晶科技股份有限公司。前述交易係屬共同控制下之組織重組，是以應追溯視為自始取得或除列，並重編比較期間之合併財務報告，是項重編使民國 107 年 12 月 31 日之共同控制下前手權益及後手權益分別調整新台幣 25,295,906 仟元及(197,512)仟元，民國 107 年度共同控制下前手權益及後手權益綜合損益總額分別調整新台幣 5,892,189 仟元及 12,032 仟元。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃裕峰 會計師 鍾鳴遠

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中華民國 109 年 3 月 9 日

力晶科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	108年12月31日 金額	%	107年12月31日（重編後並經查核） 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二六）	$ 4,171,645	6	$ 7,179,924	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二六）	4,372	-	7,151	-
1170	應收帳款－非關係人淨額（附註四、八及二六）	5,344,970	7	6,251,317	9
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、八、二六及二七）	49,914	-	129,542	-
1200	其他應收款（附註四、二六及二七）	454,119	-	570,547	1
130X	存貨（附註四、九及二七）	6,385,497	9	6,743,775	10
1410	預付款項（附註二九）	661,675	1	815,382	1
1476	其他金融資產－流動（附註四、六、二六及二八）	536,531	1	761,879	1
1479	其他流動資產－其他	192,217	-	33,117	-
11XX	流動資產總計	17,800,940	24	22,492,634	33
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、十四及二八）	47,362,848	65	40,688,694	60
1755	使用權資產（附註三、四、五、十二及二七）	4,393,945	6	-	-
1780	無形資產（附註四及十三）	241,820	-	527,062	1
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二二）	620,586	1	1,780,710	3
1915	預付設備款	1,540,275	2	1,245,100	2
1920	存出保證金（附註四、二六及二七）	8,088	-	32,010	-
1980	其他金融資產－非流動（附註四、六、二六及二八）	1,360,000	2	863,000	1
1990	其他非流動資產－其他（附註二九）	51,152	-	119,391	-
15XX	非流動資產總計	55,578,714	76	45,255,967	67
1XXX	資產總計	$ 73,379,654	100	$ 67,748,601	100

代碼	負債及權益	108年12月31日 金額	%	107年12月31日（重編後並經查核） 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十四、二六及二七）	$ -	-	$ 689,435	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及二六）	-	-	81	-
2130	合約負債－流動（附註四、二十及二七）	926,359	1	1,255,598	2
2170	應付帳款－非關係人（附註二六）	2,583,447	4	3,015,986	5
2213	應付設備款（附註二六）	1,797,230	2	2,206,140	3
2219	其他應付款（附註十五、二六及二七）	3,747,731	5	6,206,444	9
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	108	-	200,706	-
2250	負債準備－流動（附註四、十七及二六）	-	-	234,389	-
2280	租賃負債－流動（附註三、四、五、十二、二六及二七）	215,566	-	-	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十四、二六及二八）	5,512,049	8	4,580,670	7
2399	其他流動負債－其他（附註十六及二六）	1,079,733	1	438,002	1
21XX	流動負債總計	15,862,223	21	18,827,451	28
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十四、二六及二八）	21,163,213	29	15,435,055	23
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	620,586	1	1,760,110	3
2580	租賃負債－非流動（附註三、四、五、十二、二六及二七）	4,083,303	6	-	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）	1,444,727	2	1,454,058	2
2645	存入保證金（附註二六及二七）	329,221	-	311,120	-
25XX	非流動負債總計	27,641,050	38	18,960,343	28
2XXX	負債總計	43,503,273	59	37,787,794	56
	歸屬於母公司業主之權益（附註四及十九）				
3110	普通股股本	31,051,965	43	3,586,674	5
3200	資本公積	181,927	-	89,200	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	238,155	-	139,562	-
3350	未分配盈餘	(1,595,372)	(2)	1,050,937	2
3300	保留盈餘總計	(1,357,217)	(2)	1,190,499	2
3400	其他權益	(294)	-	(3,960)	-
31XX	母公司業主之權益總計	29,876,381	41	4,862,413	7
35XX	共同控制下前手權益	-	-	25,295,906	37
35XX	共同控制下後手權益	-	-	(197,512)	-
3XXX	權益總計	29,876,381	41	29,960,807	44
	負債及權益總計	$ 73,379,654	100	$ 67,748,601	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國109年3月9日查核報告）

董事長：力晶科技股份有限公司　代表人：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱豊源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股（虧損）盈餘為元

代碼		108年度 金額	108年度 %	107年度（重編後並經查核） 金額	107年度（重編後並經查核） %
4000	營業收入淨額（附註四、二十及二七）	$ 35,897,121	100	$ 49,913,779	100
5000	營業成本（附註四、九、二一及二七）	32,896,453	92	34,633,514	69
5900	營業毛利	3,000,668	8	15,280,265	31
	營業費用（附註二一及二七）				
6100	推銷費用	300,790	1	461,925	1
6200	管理費用	2,008,972	6	2,736,267	5
6300	研究發展費用	2,962,370	8	3,453,483	7
6000	營業費用合計	5,272,132	15	6,651,675	13
6500	其他收益及費損淨額（附註二一及二七）	172,685	1	258,007	-
6900	營業淨（損）利	(2,098,779)	(6)	8,886,597	18
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	62,543	-	92,564	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	(55,286)	-	126,770	-
7050	財務成本（附註四、十四、二一及二七）	(523,363)	(2)	(465,883)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	(516,106)	(2)	(246,549)	(1)
7900	稅前淨（損）利	(2,614,885)	(8)	8,640,048	17
7950	所得稅費用（附註三、四、五及二二）	(28,299)	-	(1,725,304)	(3)
8200	本年度淨（損）利	(2,643,184)	(8)	6,914,744	14

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108年度 金　額	108年度 %	107年度（重編後並經查核） 金　額	107年度（重編後並經查核） %
	其他綜合損益（附註四、十八及十九）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	($ 110,925)	-	($ 15,281)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	-	-	2,892	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(294)	-	346	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(111,219)	-	(12,043)	-
8500	本年度綜合損益總額	($ 2,754,403)	(8)	$ 6,902,701	14
	淨（損）利歸屬於：				
8610	母公司業主	($ 1,480,370)	(4)	$ 985,928	2
8615	共同控制下前手權益	(1,162,814)	(3)	5,890,576	12
8615	共同控制下後手權益	-	-	38,240	-
8600		($ 2,643,184)	(7)	$ 6,914,744	14
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	($ 1,551,814)	(5)	$ 998,480	2
8715	共同控制下前手權益	(1,162,814)	(3)	5,892,189	12
8715	共同控制下後手權益	(39,775)	-	12,032	-
8700		($ 2,754,403)	(8)	$ 6,902,701	14
	每股（虧損）盈餘（附註二三）				
9750	基　本	($ 0.94)		$ 2.56	
9850	稀　釋	($ 0.94)		$ 2.54	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 9 日查核報告）

董事長：力晶科技股份有限公司　代表人：[illegible]　經理人：謝再品　會計主管：邱垂源

力晶積[illegible]子公司

民國 108 [illegible] 月 31 日

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

代碼		歸屬於母公司業主（附註十九）												
							其他權益項目							
							國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	備供出售金融資產未實現損益		共同控制下前手權益	共同控制下後手權益	非控制權益	權益總計
		股本			保留盈餘									
		股數（仟股）	金額	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘				總計				
A1	107 年 1 月 1 日餘額	306,364	$ 3,063,642	$ 89,200	$ 81,447	$ 581,147	($ 4,127)	$ -	$ 53,136	$ 3,864,445	$ -	$ -	$ 33,088	$ 3,897,533
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	140,819	-	(70,724)	(53,136)	16,959	-	(11,223)	-	5,736
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手及後手權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,554,406	(215,792)	(33,088)	25,305,526
A5	107 年 1 月 1 日重編後餘額	306,364	3,063,642	89,200	81,447	721,966	(4,127)	(70,724)	-	3,881,404	25,554,406	(227,015)	-	29,208,795
	106 年度盈餘指撥及分配													
B1	法定盈餘公積	-	-	-	58,115	(58,115)	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	本公司股東股票股利	52,303	523,032	-	-	(523,032)	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法之投資權益變動	-	-	-	-	(543)	-	-	-	(543)	-	543	-	-
D1	107 年度淨利	-	-	-	-	985,928	-	-	-	985,928	5,890,576	38,240	-	6,914,744
D3	107 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(16,548)	(189)	29,289	-	12,552	1,613	(26,208)	-	(12,043)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	969,380	(189)	29,289	-	998,480	5,892,189	12,032	-	6,902,701
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(16,928)	-	-	-	(16,928)	-	16,928	-	-
T1	前手權益於本年度分配員工酬勞轉列股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,380	-	-	286,380
T1	前手權益於本年度分配現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,908,694)	-	-	(3,908,694)
T1	歸屬於前手權益之投資合資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,528,375)	-	-	(2,528,375)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(41,791)	-	41,791	-	-	-	-	-	-
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	358,667	3,586,674	89,200	139,562	1,050,937	(4,316)	356	-	4,862,413	25,295,906	(197,512)	-	29,960,807
	107 年度盈餘指撥及分配													
B1	法定盈餘公積	-	-	-	98,593	(98,593)	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(95,234)	-	-	-	(95,234)	-	-	-	(95,234)
B9	本公司股東股票股利	85,711	857,109	-	-	(857,109)	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	108 年度淨損	-	-	-	-	(1,480,370)	-	-	-	(1,480,370)	(1,162,814)	-	-	(2,643,184)
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(110,925)	(294)	39,775	-	(71,444)	-	(39,775)	-	(111,219)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(1,591,295)	(294)	39,775	-	(1,551,814)	(1,162,814)	(39,775)	-	(2,754,403)
N1	股份基礎給付交易	-	-	11,247	-	-	-	-	-	11,247	-	-	-	11,247
E1	現金增資	400,000	4,000,000	40,000	-	-	-	-	-	4,040,000	-	-	-	4,040,000
H3	組織重組	2,260,818	22,608,182	41,480	-	(4,078)	4,316	(40,131)	-	22,609,769	(24,593,842)	237,287	-	(1,746,786)
T1	前手權益於本年度分配員工酬勞轉列股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,750	-	-	460,750
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	[illegible]	[illegible]	181,927	$ 238,155	($ 1,595,372)	($ 294)	$ -	$ -	$ 29,876,381	$ -	$ -	$ -	$ 29,876,381

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 9 日查核報告）

董事長：力晶科技股份有限公司　代表人：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱奎源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		108 年度	107 年度（重編後並經查核）
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨（損）利	($ 2,614,885)	$ 8,640,048
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,848,177	3,926,743
A20200	攤銷費用	331,836	332,231
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失（利益）	2,698	(2,529)
A20900	財務成本	523,363	465,883
A21200	利息收入	(62,543)	(91,954)
A21300	股利收入	-	(610)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	11,247	-
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(950)	(15,983)
A23700	存貨呆滯及跌價損失	350,932	439,322
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(74,269)	41,625
A29900	負債準備提列數	-	34,389
A29900	退款負債提列（迴轉）數	31,723	(69,493)
A29900	押金設算利息收入	54	7
A29900	押金設算利息費用	(1)	(6)
A29900	其　他	(1,401)	493
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款（含關係人）	899,396	(1,098,866)
A31180	其他應收款（含關係人）	36,449	(233,966)
A31200	存　貨	7,346	(1,079,556)
A31230	預付款項	44,102	2,970
A31240	其他流動資產	(160,097)	(32,735)
A32125	合約負債	(140,971)	766,041
A32150	應付帳款	(432,539)	210,477
A32180	其他應付款（含關係人）	(1,858,056)	1,142,908
A32240	淨確定福利負債－非流動	(120,256)	(120,385)
A32230	其他流動負債	423,158	57,854
A33000	營運產生之淨現金流入	2,044,513	13,314,908
A33100	收取之利息	59,793	90,978
A33500	支付之所得稅	(39,505)	(437,654)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,064,801	12,968,232

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108 年度	107 年度（重編後並經查核）
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之投資	$ -	$ 17,761
B02700	取得不動產、廠房及設備	(12,169,407)	(10,425,048)
B02800	處分不動產、廠房及設備	56,666	17,837
B03700	存出保證金增加	(1,209)	(62)
B03800	存出保證金減少	873	175
B04500	取得無形資產	(35,232)	(16,997)
B06500	其他金融資產增加	(492,139)	(860,598)
B07600	收取之股利	-	610
BBBB	投資活動之淨現金流出	(12,640,448)	(11,266,322)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,250,000	1,819,435
C00200	短期借款減少	(2,939,435)	(3,119,435)
C01600	舉借長期借款	12,277,800	32,231,771
C01700	償還長期借款	(5,676,344)	(17,662,076)
C03000	存入保證金增加	210,311	268,104
C03100	存入保證金減少	(72,983)	(140,494)
C04000	應付租賃款減少	-	(3,218,567)
C04020	租賃負債本金償還	(98,666)	-
C04500	發放現金股利	(95,234)	(3,908,694)
C04600	現金增資	4,040,000	-
C05600	支付之利息	(407,151)	(457,402)
C09900	其他預付款項	-	(93,000)
C09900	共同控制下前手權益減少數	(1,920,633)	(2,528,375)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	7,567,665	3,191,267
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(297)	350
EEEE	本年度現金及約當現金淨（減少）增加數	(3,008,279)	4,893,527
E00100	年初現金及約當現金餘額	7,179,924	2,286,397
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 4,171,645	$ 7,179,924

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 9 日查核報告）

董事長：力晶科技股份有限公司　代表人：[illegible]　經理人：謝再居　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併財務報表附註

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（除另註明外，金額以新台幣仟元為單位）

一、公司沿革

力晶積成電子製造股份有限公司（以下稱「力積電公司」）原名為鉅晶電子股份有限公司，係由力晶科技股份有限公司（以下稱「力晶公司」）分割設立，以 97 年 4 月 1 日為分割基準日，並經科學工業園區管理局核准設立。主要營業項目為從事各式積體電路之研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工及銷售。力積電公司及其子公司以下合稱「本公司」。

力晶公司為重整集團組織架構，進行以下組織重整，其交易因屬共同控制下之組織重組，應視為自始即已合併而追溯重編前期比較財務報表：

(一) 力積電公司於 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業，並由力積電公司發行新股予力晶公司作為收購之對價；及由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd. （以下稱「Global Powertec 公司」）讓與力積電公司；

(二) 108 年 4 月 1 日由力積電公司將持股 100%之富碩投資股份有限公司（以下稱「富碩公司」）及 Sprout International Limited（以下稱「Sprout 公司」）全數出售予力晶公司。

本合併財務報告係以力積電公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告於 109 年 3 月 9 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則

（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

除下列說明外，適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動：

1. 國際財務報導準則第 16 號「租賃」

國際財務報導準則第16號規範租賃協議之辨認與出租人及承租人會計處理，該準則將取代國際會計準則第 17 號「租賃」及國際財務報導解釋第 4 號「決定一項安排是否包含租賃」等相關解釋。相關會計政策請參閱附註四。

<u>租賃定義</u>

本公司選擇僅就 108 年 1 月 1 日以後簽訂（或變動）之合約依國際財務報導準則第 16 號評估是否係屬（或包含）租賃，先前已依國際會計準則第 17 號及國際財務報導解釋第 4 號辨認為租賃之合約不予重新評估並依國際財務報導準則第 16 號之過渡規定處理。

<u>本公司為承租人</u>

除低價值標的資產租賃及短期租賃選擇按直線基礎認列費用外，其他租賃係於合併資產負債表認列使用權資產及租賃負債。合併綜合損益表係分別表達使用權資產之折舊費用及租賃負債按有效利息法所產生之利息費用且於合併現金流量表將償付租賃負債之本金金額及支付利息部分皆表達為籌資活動。適用國際財務報導準則第 16 號前，分類為營業租賃之合約係按直線基礎認列費用。營業租賃現金流量於合併現金流量表係表達於營業活動。分類為融資租賃之合約係於合併資產負債表認列租賃資產及應付租賃款。

本公司選擇將追溯適用國際財務報導準則第16號之累積影響數調整於首次適用日，不重編比較資訊。

先前依國際會計準則第 17 號以營業租賃處理之協議，除短期租賃外，其他租賃於 108 年 1 月 1 日租賃負債之衡量係以剩餘租賃給付按該日承租人之增額借款利率折現，使用權資產係以該日之租賃負債金額並調整先前已認列之預付或應付租賃給付金額衡量。所認列之使用權資產均適用國際會計準則第 36 號評估減損。

本公司對 108 年 1 月 1 日使用權資產亦適用下列權宜作法：

(1) 對具有合理類似特性之租賃組合使用單一折現率衡量租賃負債。

(2) 租賃期間於 108 年 12 月 31 日以前結束之租賃依短期租賃處理。

(3) 不將原始直接成本計入 108 年 1 月 1 日之使用權資產衡量中。

(4) 進行租賃負債之衡量時，對諸如租賃期間之決定依 108 年 1 月 1 日之預計使用情形。

本公司於 108 年 1 月 1 日認列租賃負債所適用之增額借款利率加權平均數為 2.85%，該租賃負債金額與 107 年 12 月 31 日不可取消營業租賃之未來最低租賃給付總額之差異說明如下：

107 年 12 月 31 日不可取消營業租賃之未來最低租賃給付總額	$1,597,354
減：適用豁免之短期租賃	(4,588)
108 年 1 月 1 日未折現總額	$1,592,766
按 108 年 1 月 1 日增額借款利率折現後之現值	$1,292,489
加：因延長租賃使用權產生之調整	534,793
108 年 1 月 1 日租賃負債餘額	$1,827,282

本公司為出租人

於過渡時對出租人之租賃不作任何調整，且自 108 年 1 月 1 日起始適用國際財務報導準則第 16 號。

首次適用國際財務報導準則第 16 號對 108 年 1 月 1 日各資產、負債及權益項目調整如下：

	108年1月1日重編前金額	首次適用之調整	108年1月1日重編後金額
使用權資產	$ -	$ 1,827,282	$ 1,827,282
資產影響	$ -	$ 1,827,282	$ 1,827,282
租賃負債－流動	$ -	$ 94,723	$ 94,723
租賃負債－非流動	-	1,732,559	1,732,559
負債影響	$ -	$ 1,827,282	$ 1,827,282

2. 國際財務報導解釋第 23 號「所得稅務處理之不確定性」

國際財務報導解釋第 23 號釐清當存有所得稅務處理之不確定性時，本公司須假設稅務機關將可取具所有相關資料進行審查，若判斷其申報之稅務處理很有可能被稅務機關接受，本公司對於課稅所得、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用課稅抵減及稅率之決定必須與申報所得稅時所採用之稅務處理一致。若稅務機關並非很有可能接受申報之稅務處理，本公司須採最可能金額或預期值（應採兩者中較能預測不確定性最終結果之方法）評估。若事實及情況改變，本公司須重評估其判斷與估計。

(二) 109 年適用之金管會認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會（IASB）發布之生效日
國際財務報導準則第 3 號之修正「業務之定義」	2020 年 1 月 1 日（註 1）
國際財務報導準則第 9 號、國際會計準則第 39 號及國際財務報導準則第 7 號之修正「利率指標變革」	2020 年 1 月 1 日（註 2）
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「重大性之定義」	2020 年 1 月 1 日（註 3）

註 1： 收購日在年度報導期間開始於 2020 年 1 月 1 日以後之企業合併及於前述日期以後發生之資產取得適用此項修正。

註 2： 2020 年 1 月 1 日以後開始之年度期間追溯適用此項修正。

註 3： 2020 年 1 月 1 日以後開始之年度期間推延適用此項修正。

截至本合併財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註1)
國際財務報導準則第 10 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未　定
國際財務報導準則第 17 號「保險合約」	2021 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「將負債分類為流動或非流動」	2022 年 1 月 1 日

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

截至本合併財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRSs 編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。歷史成本通常係依取得資產所支付對價之公允價值決定。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。

3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債（即使於資產負債表日後至通過發布財務報告前已完成長期性之再融資或重新安排付款協議，亦屬流動負債），以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 合併基礎

本合併財務報告係包含力積電公司及由力積電公司所控制個體（子公司）之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整，以使其會計政策與本公司之會計政策一致。於編製合併財務報告時，各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至本公司業主及非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。

子公司明細、持股比率及營業項目，參閱附註十及附表二。

(五) 企業合併

企業合併係採收購法處理。收購相關成本於成本發生及勞務取得當期列為費用。

商譽係按移轉對價之公允價值、被收購者之非控制權益金額以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日之公允價值之總額，超過收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額衡量。

(六) 外　　幣

各個體編製財務報告時，以個體功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。除為規避部分匯率風險而進行避險交易所產生之兌換差額外，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製合併財務報告時，本公司國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額列於其他綜合損益。

若本公司處分國外營運機構之所有權益，或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制，或處分國外營運機構之聯合協議或關聯企業後之保留權益係金融資產並按金融工具之會計政策處理，所有與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制，係按比例將累計兌換差額併入權益交易計算，但不認列為損益。

在部分處分國外營運機構之關聯企業未構成對該關聯企業喪失重大影響時，認列於其他綜合損益之累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

(七) 存　　貨

存貨包括原料、在製品及製成品，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目

為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。另固定製造費用應按生產設備之正常產能分攤，因產能較低或設備閒置導致之未分攤固定製造費用，應於發生當年度認列銷貨成本。

本公司之存貨平時按標準成本計價，結帳日再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。

(八) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損損失後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(九) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，並且於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視。並推延適用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除　　列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(十) 有形、無形資產及合約成本相關資產之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至個別現金產生單位。

針對非確定耐用年限及尚未可供使用之無形資產，至少每年及有減損跡象時進行減損測試。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

適用國際財務報導準則第 15 號之客戶合約，因客戶合約所認列之存貨、不動產、廠房及設備及無形資產先依存貨減損規定及上述規定認列減損，次依合約成本相關資產之帳面金額超過提供相關商品或勞務預期可收取之對價剩餘金額扣除直接相關成本後之金額認列為減損損失，續將合約成本相關資產之帳面金額計入所屬現金產生單位，以進行現金產生單位之減損評估。

當減損損失於後續迴轉時，該資產、現金產生單位或合約成本相關資產之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產、現金產生單位或合約成本相關資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十一) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於合併資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或

發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

金融資產係分為透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資及按攤銷後成本衡量之金融資產。

A.透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產係強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。其產生之利益或損失係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

B.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

本公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，其後續公允價值變動認列於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於本公司具收款之權利時認列於損益，除非該收款之權利明顯代表部分投資成本之回收。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

C.按攤銷後成本衡量

現金及約當現金、債務工具投資、應收帳款（含關係人）、其他應收款項、受限制存款及存出保證金係按攤銷後成本衡量。

債務工具投資之合約條款為完全支付本金及流通在外本金金額之利息，且持有目的係以收取合約現金流量，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

按攤銷後成本衡量之各類金融資產於原始認列後，係以有效利息法決定之帳面價值減除任何減損損失之攤銷後成本衡量。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產及合約資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）。

應收帳款按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

於一按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。於一透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

2. 權益工具

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

3. 金融負債

(1) 後續衡量

除透過損益按公允價值衡量之金融負債外，所有金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量：

透過損益按公允價值衡量之金融負債

透過損益按公允價值衡量之金融負債包含持有供交易之金融負債。

持有供交易之金融負債係按公允價值衡量，其再衡量產生之利益或損失（包含該金融負債所支付之任何股利或利息）係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

4. 衍生工具

本公司簽訂之衍生工具包括遠期外匯合約，用以管理本公司之匯率風險。

衍生工具於簽訂衍生工具合約時，原始以公允價值認列，後續於資產負債表日按公允價值再衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

(十二) 負債準備

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所需支出之最佳估計。負債準備係以清償義務之估計現金流量折現值衡量。

(十三) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，並於滿足各履約義務時認列收入。

商品銷貨收入

商品銷貨收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。本公司基於歷史經驗及考量不同之合約條件，以估計可能發生之銷貨退回及折讓，據以認列退款負債。

商品銷貨收入來自矽晶圓產品之銷售。產品於出貨時或運抵客戶指定地點時認列收入及應收帳款。銷售之預收款項，於商品認列收入前係認列為合約負債。

(十四) 租　　賃

108 年

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 本公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

本公司於轉租使用權資產時，係以使用權資產（而非標的資產）判斷轉租之分類。惟若主租賃係本公司適用認列豁免之短期租賃時，該轉租分類為營業租賃。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。因取得營業租賃所發生之原始直接成本，係加計至標的資產之帳面金額，並按直線基礎於租賃期間內認列為費用。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為收益。

2. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於合併資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。若租賃期間屆滿時將取得標的資產所有權，或若使用權資產之成本反映購買選擇權之行使，則自租賃開始日起至標的資產耐用年限屆滿時提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於合併資產負債表。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為費用。

<u>107 年</u>

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

1. 本公司為出租人

營業租賃之租賃收益係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。因協商與安排營業租賃所產生之原始直接成本，係加計至出租資產之帳面金額，並按直線基礎於租賃期間內認列為費用。營業租賃下，或有租金於發生當期認列為收益。

2. 本公司為承租人

融資租賃係以各期最低租賃給付現值總額或租賃開始日租賃資產公允價值較低者作為成本入帳，並同時認列應付租賃款負債。

每期所支付租賃款之隱含利息列為當期財務費用，若可直接歸屬於符合要件之資產者，則予以資本化。

營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用。

營業租賃所取得之租賃誘因係認列為負債。誘因利益總額按直線基礎認列為租金費用之減項。

租賃協議之或有租金於發生當認列為費用。

(十五) 借款成本

直接可歸屬於取得及建造符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，所有其他借款成本係於發生當期認列為損益。

(十六) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務之期間，將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服務成本及前期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時、計畫修正或縮減時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益、資產上限影響數之變動及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債係確定福利退休計畫之提撥短絀。

(十七) 股份基礎給付協議

給與員工之員工認股權

員工認股權係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。本公司辦理現金增資保留員工認購，係確認員工認購股數之日為給與日。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積。

(十八) 所得稅

所得稅費用係當期應付所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依我國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司、關聯企業及合資權益相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資及權益有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能有足夠課稅所得用以實現暫時性差異之利益，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、<u>重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源</u>

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

管理階層將對估計與基本假設持續檢視。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

重大會計判斷

(一) 租賃期間（適用於 108 年）

決定所承租資產之租賃期間時，本公司考量將產生經濟誘因以行使（或不行使）選擇權之所有攸關事實及情況，包括自租賃開始日至選擇權行使日間所有事實及情況之預期變動。考量主要因素包括選擇權所涵蓋期間之合約條款及條件、於合約期間進行之重大租賃權益改良及標的資產對承租人營運之重要性等。於本公司控制範圍內重大事項或情況重大改變發生時，重評估租賃期間。

估計及假設不確定性之主要來源

(一) 所得稅

遞延所得稅資產係於未來很有可能有足夠之課稅所得供可減除暫時性差異使用時方予以認列。評估遞延所得稅資產之可實現性時，必須涉及管理階層之重大會計判斷及估計，包含預期未來銷貨收入成長及利潤率、可使用之所得稅抵減及稅務規畫等假設。任何關於全球經濟環境、產業環境的變遷及法令的改變，均可能引起遞延所得稅資產之重大調整。

(二) 承租人增額借款利率（適用於 108 年）

決定租賃給付折現所使用之承租人增額借款利率，係以相當存續期間及幣別之無風險利率做為參考利率，並將所估計之承租人信用風險貼水及租賃特定調整（例如，資產特性及附有擔保等因素）納入考量。

六、現金及約當現金

	108年12月31日	107年12月31日
活期存款	$ 2,044,064	$ 3,161,513
支票存款	15,780	69,055
庫存現金	106	133
約當現金		
銀行定期存款	3,708,226	4,564,102
附買回債券	300,000	1,010,000
	6,068,176	8,804,803
受限制存款（帳列其他金融資產）	(1,896,531)	(1,624,879)
合　　計	$ 4,171,645	$ 7,179,924

銀行存款及附買回債券於資產負債表日之市場利率區間如下：

	108年12月31日	107年12月31日
銀行存款	0%~2.60%	0%~3.85%
附買回債券	0.53%	0.47%~0.53%

七、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債

	108年12月31日	107年12月31日
金融資產－流動		
強制透過損益按公允價值衡量		
衍生工具		
－遠期外匯合約	$ 4,372	$ 7,151
金融負債－流動		
持有供交易		
衍生工具		
－遠期外匯合約	$ -	$ 81

於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下：

	幣別	到期期間	合約金額（仟元）
108年12月31日			
賣出遠期外匯	美金兌新台幣	109.01.03	USD 5,000/ NTD 152,300
	美金兌日圓	109.01.06~109.01.30	USD 13,736/ JPY 1,500,000
107年12月31日			
賣出遠期外匯	美金兌新台幣	108.01.03~108.02.12	USD 51,000/ NTD1,568,650
	美金兌日圓	108.01.08~108.02.14	USD 11,697/ JPY 1,300,000

本公司從事遠期外匯交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。

八、應收帳款

	108年12月31日	107年12月31日
按攤銷後成本衡量		
應收帳款－非關係人	$ 5,344,970	$ 6,251,317
減：備抵損失	-	-
	5,344,970	6,251,317
應收帳款－關係人	49,914	129,542
減：備抵損失	-	-
	49,914	129,542
應收帳款淨額	$ 5,394,884	$ 6,380,859

本公司對商品銷售之平均授信期間為月結 30～60 天，應收帳款不予計息。為減輕信用風險，本公司管理階層依公司相關之政策、程序及內部控制，指派專責團隊負責授信作業及其他監控程序，以確保逾期應收帳款之回收已採取適當行動，並按權責由管理階層負責授信額度之決定及授信核准。此外，本公司會定期逐一複核應收帳款之可回收金額以確保無法回收之應收帳款項已提列適當減損損失。

本公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量 GDP 預測及產業展望。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期，本公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

108 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期 超過 90 天	合計
總帳面金額	$4,620,136	$ 768,649	$ 6,099	$ -	$ -	$5,394,884
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$4,620,136	$ 768,649	$ 6,099	$ -	$ -	$5,394,884

107 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期 超過 90 天	合計
總帳面金額	$4,653,894	$1,064,568	$ 430,803	$ 7,271	$ 224,323	$6,380,859
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$4,653,894	$1,064,568	$ 430,803	$ 7,271	$ 224,323	$6,380,859

九、存　　貨

	108年12月31日	107年12月31日
製成品	$ 542,260	$ 800,935
在製品	3,842,467	3,617,975
原　料	2,000,770	2,324,865
	$ 6,385,497	$ 6,743,775

108 及 107 年度與存貨相關之銷貨成本分別為 32,896,453 仟元及 34,633,514 仟元。

108 及 107 年度之銷貨成本包括實際產能使用較低所導致之未分攤固定製造費用分別為 3,064,643 仟元及 703,241 仟元，及分別提列存貨呆滯及跌價損失 350,932 仟元及 439,322 仟元。

十、子公司

列入合併財務報告之子公司

本合併財務報告編製主體如下：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比 108年12月31日	所持股權百分比 107年12月31日（重編後）	說明
力積電公司	Global Powertec Co., Ltd.（Global Powertec 公司）	各項投資業務	100%	100%	註一
Global Powertec 公司	PowerMemory Inc.（PowerMemory 公司）	半導體及各式電子產品開發、製造、銷售及輸出入	100%	100%	
	Maxram Inc.（Maxram 公司）	半導體及各式電子產品開發、製造、銷售及輸出入	100%	-	註二

註一：本公司為重整集團組織架構，於 108 年 4 月 1 日由力積電公司將持股 100%之富碩公司及 Sprout 公司全數出售予力晶公司；於 108 年 5 月 1 日由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec 公司依企業併購法讓與力積電公司。前述交易屬共同控制下組織重組，視為自始合併而追溯重編前期比較財務報表。

註二：Global Powertec 公司於 108 年 3 月 22 日取得該公司 100%之股權。

十一、不動產、廠房及設備

	108年12月31日
自　用	$ 47,362,848

(一) 自用－108 年

	108年12月31日	107年12月31日
房屋及建築	$ 4,380,121	$ 4,464,421
機器設備	31,651,873	25,363,513
研發設備	1,837,813	1,197,621
廠務設備	6,207,126	5,153,233
運輸設備	2,719	1,599
生財器具	82,070	81,293
租賃改良	2,859	578
其他設備	120,452	127,742
待驗設備及未完工程	3,077,815	4,298,694
	$ 47,362,848	$ 40,688,694

	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
	年初餘額	增加	出售或報廢	淨兌換差額	科目移轉	年底餘額
成本						
房屋及建築	$ 11,527,161	$ -	$ -	$ -	$ 133,532	$ 11,660,693
機器設備	201,763,144	-	(4,145,292)	-	9,956,481	207,574,333
研發設備	2,064,558	-	(5,918)	-	958,631	3,017,271
廠務設備	29,605,077	-	(5,138)	-	1,464,974	31,064,913
運輸設備	10,239	-	-	-	1,460	11,699
生財器具	604,613	974	(8,336)	(13)	37,130	634,368
租賃改良	1,216	2,398	-	(16)	-	3,598
其他設備	1,783,576	-	(4,626)	-	75,935	1,854,885
	247,359,584	$ 3,372	($ 4,169,310)	($ 29)	$ 12,628,143	255,821,760
累計折舊						
房屋及建築	7,062,740	$ 217,832	$ -	$ -	$ -	7,280,572
機器設備	176,361,044	3,804,839	(4,088,777)	-	(193,233)	175,883,873
研發設備	866,937	126,983	(5,918)	-	191,456	1,179,458
廠務設備	24,451,844	411,078	(5,135)	-	-	24,857,787
運輸設備	8,640	340	-	-	-	8,980
生財器具	523,320	37,318	(8,336)	(4)	-	552,298
租賃改良	638	105	-	(4)	-	739
其他設備	1,655,834	81,798	(4,626)	-	1,427	1,734,433
	210,930,997	$ 4,680,293	($ 4,112,792)	($ 8)	($ 350)	211,498,140
累計減損						
機器設備	38,587	$ -	$ -	$ -	$ -	38,587
待驗設備及未完工程	4,298,694	$ 11,407,264	$ -	$ -	($ 12,628,143)	3,077,815
淨額	$ 40,688,694					$ 47,362,848

(二) 107 年

	107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
	年初餘額	增加	出售或報廢	淨兌換差額	科目移轉	年底餘額
成本						
房屋及建築	$ 10,262,282	$ -	$ -	$ -	$ 1,264,879	$ 11,527,161
機器設備	195,955,302	-	(794,744)	-	6,602,586	201,763,144
研發設備	818,084	-	(1,039)	-	1,247,513	2,064,558
廠務設備	27,706,920	-	(4,398)	-	1,902,555	29,605,077
運輸設備	10,747	-	(508)	-	-	10,239
生財器具	564,677	-	(9,362)	76	49,222	604,613
租賃資產	3,328,288	-	-	-	(3,328,288)	-
租賃改良	1,159	-	-	57	-	1,216
其他設備	1,693,725	-	(4,289)	-	94,140	1,783,576
	240,341,184	$ -	($ 814,340)	$ 133	$ 7,832,607	247,359,584
累計折舊						
房屋及建築	6,885,974	$ 176,766	$ -	$ -	$ -	7,062,740
機器設備	173,773,395	3,159,412	(793,608)	-	221,845	176,361,044
研發設備	486,481	49,015	(1,039)	-	332,480	866,937
廠務設備	24,190,339	265,641	(4,136)	-	-	24,451,844
運輸設備	8,829	319	(508)	-	-	8,640
生財器具	505,319	27,341	(9,362)	22	-	523,320
租賃資產	352,761	201,564	-	-	(554,325)	-
租賃改良	546	63	-	29	-	638
其他設備	1,613,501	46,622	(4,289)	-	-	1,655,834
	207,817,145	$ 3,926,743	($ 812,942)	$ 51	$ -	210,930,997
累計減損						
機器設備	38,986	$ -	($ 399)	$ -	$ -	38,587
待驗設備及未完工程	2,445,763	$ 9,685,538	$ -	$ -	($ 7,832,607)	4,298,694
淨額	$ 34,930,816					$ 40,688,694

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

房屋及建築	21 至 40 年
機器設備	1.5 至 19 年
研發設備	1.5 至 19 年
廠務設備	6 至 30 年
運輸設備	6 年
生財器具	4 至 7 年
租賃資產	6 至 19 年
租賃改良	4 至 16 年
其他設備	4 年

本公司設定質押作為借款擔保之不動產、廠房及設備金額，請參閱附註十四及二八。

十二、租賃協議

(一) 使用權資產－108 年

	108年12月31日
使用權資產帳面金額	
土　　地	$ 1,523,791
建 築 物	149,983
機器設備	2,696,447
運輸設備	23,724
	$ 4,393,945

	108年度
使用權資產之增添	$ 2,768,430
使用權資產之折舊費用	
土　　地	$ 70,872
建 築 物	32,236
機器設備	55,120
運輸設備	9,656
	$ 167,884

(二) 租賃負債－108 年

	108年12月31日
租賃負債帳面金額	
流　　動	$ 215,566
非 流 動	$ 4,083,303

租賃負債之折現率區間如下：

	108年12月31日
土　　地	2.92%
建 築 物	1.79%~2.64%
機器設備	1.83%~4.58%
運輸設備	1.79%~1.97%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租若干土地及建築物做為廠房及辦公室使用，主要租賃期間為 20 年。位於中華民國之土地租賃約定每 2 年依公告地價調整租賃給付。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之土地及建築物並無優惠承購權。

本公司承租若干公務車以供營業使用，租賃期間為 3～4 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之公務車並無優惠承購權。

(四) 其他租賃資訊

108 年

	108年度
短期租賃費用	$ 16,672
租賃之現金流出總額（含使用權資產）	$158,640

本公司選擇對符合短期租賃之機器設備與公務車租賃適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

107 年

不可取消營業租賃之未來最低租賃給付總額如下：

	107年12月31日
不超過 1 年	$ 145,279
1～5 年	544,161
超過 5 年	907,914
	$ 1,597,354

十三、無形資產

	108年12月31日	107年12月31日
技術移轉及授權費	$ 55,876	$320,696
專 利 權	136,454	166,800
電腦軟體設備及系統費	45,180	29,982
其　　他	4,310	9,584
	$241,820	$527,062

	技術移轉及授權費	電腦軟體設備及系統費	專利權	其他	合計
成　本					
108年1月1日餘額	$1,324,100	$ 181,484	$ 307,550	$ 27,699	$1,840,833
增　添	-	46,594	-	-	46,594
本期攤提完畢	-	(159,589)	-	(18,732)	(178,321)
淨兌換差額	-	(1)	-	-	(1)
108年12月31日餘額	$1,324,100	$ 68,488	$ 307,550	$ 8,967	$1,709,105
累計攤銷					
108年1月1日餘額	$1,003,404	$ 151,502	$ 140,750	$ 18,115	$1,313,771
攤銷費用	264,820	31,396	30,346	5,274	331,836
本期攤提完畢	-	(159,589)	-	(18,732)	(178,321)
淨兌換差額	-	(1)	-	-	(1)
108年12月31日餘額	$1,268,224	$ 23,308	$ 171,096	$ 4,657	$1,467,285
107年12月31日及108年1月1日淨額	$ 320,696	$ 29,982	$ 166,800	$ 9,584	$ 527,062
108年12月31日淨額	$ 55,876	$ 45,180	$ 136,454	$ 4,310	$ 241,820
成　本					
107年1月1日餘額	$1,324,100	$ 179,797	$ 307,550	$ 27,699	$1,839,146
增　添	-	15,963	-	-	15,963
重 分 類	-	(580)	-	-	(580)
本期攤提完畢	-	(13,715)	-	-	(13,715)
淨兌換差額	-	19	-	-	19
107年12月31日餘額	$1,324,100	$ 181,484	$ 307,550	$ 27,699	$1,840,833
累計攤銷					
107年1月1日餘額	$ 738,584	$ 134,619	$ 110,402	$ 11,734	$ 995,339
攤銷費用	264,820	30,682	30,348	6,381	332,231
重 分 類	-	(87)	-	-	(87)
本期攤提完畢	-	(13,715)	-	-	(13,715)
淨兌換差額	-	3	-	-	3
107年12月31日餘額	$1,003,404	$ 151,502	$ 140,750	$ 18,115	$1,313,771
107年12月31日淨額	$ 320,696	$ 29,982	$ 166,800	$ 9,584	$ 527,062

技術移轉及授權費主要係本公司支付予 Micron Memory Japan, Inc.（原 Elpida Memory Inc.）移轉及授權使用若干製造動態隨機存取記憶體技術之費用。

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

技術移轉及授權費	5 年
電腦軟體設備及系統費	2 年
專 利 權	10 至 15 年
其　　他	2 至 5 年

十四、借　　款

(一) 短期借款

	108年12月31日	107年12月31日
無擔保借款		
－銀行借款	$ -	$200,000
－關係人借款（參閱附註二七）	-	489,435
	$ -	$689,435

銀行借款之利率於 107 年 12 月 31 日為 1.85%。

(二) 長期借款

	108年12月31日	107年12月31日
擔保借款		
－長期抵押聯合貸款(一)	$20,064,077	$15,773,910
－長期抵押聯合貸款(二)	3,941,600	2,766,096
－長期抵押聯合貸款(三)	1,279,285	-
－中長期借款(四)	-	62,500
－其　　他	865,300	-
小　　計	26,150,262	18,602,506
無擔保借款		
－銀行借款	525,000	608,334
其他借款		
－其　　他	-	804,885
小　　計	525,000	1,413,219
	26,675,262	20,015,725
減：列為 1 年內到期部分	(5,512,049)	(4,580,670)
長期借款	$21,163,213	$15,435,055

力晶公司於 107 年 3 月 14 日簽署長期抵押聯合貸款(一)之授信合約、分別於 107 年 12 月 10 日及 108 年 12 月 25 日簽署第一次及

第二次增補合約，授信額度變更為新臺幣 24,500,000 仟元。依聯貸合約約定按季還本，到期日為 112 年 12 月，108 及 107 年 12 月 31 日有效利率皆為 1.79%。主要承諾事項如下：

1. 力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，將聯合授信合約下之權利義務，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，本授信案由力積電公司擔任借款人。
2. 力積電公司需於額度管理銀行開立營運收支專戶該專戶之餘額應於每季末檢視當季累積存（匯）入金額不得低於新台幣 6,000,000 仟元或等值外幣。
3. 力積電公司於本授信案期間，每年資本支出加計非資本支出及現金股利之支出限額，不得超逾前一年度之稅後淨利加計折舊並扣除特別保留份額。非資本支出，係指包括借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款及與借款人本業相關之長、短期投資股票或股權支出。但借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款屬借新還舊者不在此限。前述支出限額，依第二次增補合約規定，109 年為一固定限額，自 110 年起則不得超逾前一期期末之稅後淨利減除重大無現金流量之收入，加計折舊並扣除特別保留份額。
4. 力積電公司於本授信案期間，每季需提供經額度管理銀行同意之會計師就資本支出、支出限額及相關約定之查核或檢核報告予額度管理銀行。
5. 於債務清償前，力積電公司之年度合併財務報表受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之限制。

力積電公司截至 108 年 12 月 31 日止之各項財務比率未符合合約規定。依合約約定期限內未予改善，需支付一定比例之補償費及罰款，則財務比率之違反不視為發生違約情事。

長期抵押聯合貸款(二)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 114 年 1 月，截至 108 及 107 年 12 月 31 日有效利率分別為 1.86% 及 1.96%。另聯貸合約規定，力積電公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之

限制。力積電公司因 107 年度個體財務報告之流動比率小於 100%，惟已依貸款合約規定期限內完成改善。

長期抵押聯合貸款(三)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 113 年 2 月，截至 108 年 12 月 31 日有效利率為 1.86%。另聯貸合約規定，力積電公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有負債比率、流動比率及利息保障倍數等限制。力積電公司截至 108 年 12 月 31 日止之各項財務比率均符合合約規定。

中長期借款(四)依合約規定於每季償付至 108 年 7 月到期，截至 107 年 12 月 31 日止，有效年利率為 2.09%，前述借款已於 108 年 3 月提前清償完畢。

長期借款擔保之情形，請參閱附註二八。

力晶公司分別於 106 年 2 月、106 年 9 月及 106 年 12 月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約約定按季還本，到期日為 109 年 2 月至 109 年 12 月，部分借款已於 108 年 4 月提前清償。截至 108 年 12 月 31 日止，年利率為 1.71%至 2.04%。

力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於 108 年 4 月簽署中長期授信增補合約，將授信合約下之債務、權利及義務，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，前述無擔保銀行中長期額度貸款由力積電公司擔任借款人。

力積電公司分別於 108 年 5 月及 108 年 7 月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約規定每半年還本，到期日分別為 111 年 5 月及 110 年 7 月，截至 108 年 12 月 31 日止，年利率皆為 1.60%。

其他借款：力晶公司於 106 年 5 月至 10 月與金士頓公司承作設備買賣融資借款，相關款項於到期日 108 年 10 月一次支付。依設備買賣融資需支付價款設算隱含利率約為 2.78%至 2.89%。力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，本融資借款由力積電公司擔任借款人。前述借款於 108 年 9 月簽署增補合約，對方約定於 110 年 10 月一次清償借款，截至 108 年 12 月 31 日止，年利率為 1.80%。擔保之情形請參閱附註二八。

十五、其他應付款

	108年12月31日	107年12月31日
應付薪資及獎金	$ 1,231,066	$ 1,416,294
應付權利金	488,941	339,407
應付電費	188,870	182,526
應付利息	120,733	107,601
應付員工及董監酬勞	-	2,350,650
其　　他	1,718,121	1,809,966
	$ 3,747,731	$ 6,206,444

十六、其他流動負債

	108年12月31日	107年12月31日
退款負債	$ 191,000	$ 159,277
存入保證金	161,647	-
其　　他	727,086	278,725
	$ 1,079,733	$ 438,002

十七、負債準備－流動

	108年12月31日	107年12月31日
訴訟案件	$ -	$234,389

	訴　訟　案　件
108 年 1 月 1 日餘額	$234,389
共同控制下前手權益轉出數	(234,389)
108 年 12 月 31 日餘額	$ -
107 年 1 月 1 日餘額	$200,000
本期新增	34,389
本期使用	-
107 年 12 月 31 日餘額	$234,389

訴訟案件係依最有可能之賠償金額並加計利息估計。

日本 Toshiba 公司於 103 年 5 月在台灣智慧財產法院控訴力晶公司等數名被告應連帶付給 Toshiba 公司新台幣 2 億元之專利侵權損害賠償金，於 106 年 7 月經智慧財產法院一審宣判應連帶給付賠償金及按年息百分之五計算之利息。力晶公司就此已提列等額之負債準備且於 106 年 7 月 19 日至新竹地院提存所提 2 億元預供擔保以免假執行，並於 106 年 7 月 31 日進行上訴救濟。於 108 年 5 月 1 日進行母子間組織重組時，基於法律責任將前述負債準備及相關擔保保留於力晶公司。

十八、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

力積電公司適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

(二) 確定福利計畫

力積電公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。該等公司按員工每月薪資總額 2%提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，該等公司並無影響投資管理策略之權利。

列入合併資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	108年12月31日	107年12月31日
已提撥確定福利義務之現值	$ 2,605,324	$ 2,467,078
計畫資產公允價值	(1,040,191)	(892,586)
淨確定福利負債	$ 1,565,133	$ 1,574,492

淨確定福利負債變動如下：

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
107 年 1 月 1 日	$ 2,441,031	($ 797,426)	$ 1,643,605
當期服務成本	24,680	-	24,680
利息費用（收入）	30,116	(10,152)	19,964
認列於損益	54,796	(10,152)	44,644
再衡量數			
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	-	(21,055)	(21,055)
精算損失－人口統計假設變動	11,204	-	11,204

（接次頁）

（承前頁）

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
精算損失－財務假設變動	$ 23,707	$ -	$ 23,707
精算損失－經驗調整	1,425	-	1,425
認列於其他綜合損益	36,336	(21,055)	15,281
雇主提撥	-	(119,222)	(119,222)
福利支付	(65,085)	55,269	(9,816)
107 年 12 月 31 日	2,467,078	(892,586)	1,574,492
當期服務成本	17,760	-	17,760
利息費用（收入）	14,696	(5,239)	9,457
認列於損益	32,456	(5,239)	27,217
再衡量數			
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	-	(991)	(991)
精算損失－人口統計假設變動	3,943	-	3,943
精算損失－財務假設變動	115,082	-	115,082
精算損失－經驗調整	(7,109)	-	(7,109)
認列於其他綜合損益	111,916	(991)	110,925
雇主提撥	-	(72,834)	(72,834)
福利支付	(21,135)	6,989	(14,146)
認列人口併入影響數	15,009	(75,530)	(60,521)
108 年 12 月 31 日	$2,605,324	($1,040,191)	$1,565,133

力積電公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟力積電公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行 2 年定期存款利率。如有低於該利率之情形，由國庫補足。。
2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

力積電公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	108年12月31日	107年12月31日
折 現 率	0.75%	1.00%
薪資預期增加率	4.25%	3.00%~4.25%
離 職 率	0.71%	0.53%~1.23%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	108年12月31日	107年12月31日
折 現 率		
增加 0.25%	($ 87,141)	($ 84,815)
減少 0.25%	$ 91,170	$ 88,856
薪資預期增加率		
增加 0.25%	$ 85,929	$ 83,719
減少 0.25%	($ 82,667)	($ 80,414)
離 職 率		
離職率 110%	($ 1,411)	($ 1,509)
離職率 90%	$ 1,415	$ 1,514

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	108年12月31日	107年12月31日
預期1年內提撥金額	$ 39,360	$131,466
確定福利義務加權平均存續期間	13 年	13 年~14 年

十九、權　　益

(一) 普通股股本

	108年12月31日	107年12月31日
額定股數（仟股）	5,000,000	1,000,000
額定股本	$50,000,000	$10,000,000
已發行且已收足股款之股數（仟股）	3,105,196	358,667
已發行股本	$31,051,965	$ 3,586,674

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為 500,000 仟股。

力積電公司股本變動主要係因股票股利、現金增資及組織重組發行新股。

力積電公司於 107 年 9 月 4 日董事會決議，為進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業（含資產、負債及營業），並由力積電公司發行新股予力晶公司作為收購之對價，計發行新股 2,260,818 仟股，並以 108 年 5 月 7 日為收購發行新股增資基準日，已於 108 年 5 月 13 日辦理變更登記完竣。

力積電公司經董事會決議現金增資發行新股，並於 108 年 6 月 28 日經董事會決議調整最終股數及募集金額，辦理現金增資發行新股 400,000 仟股，每股面額 10 元，並以每股新台幣 10.1 元發行，本次以 108 年 9 月 20 日為增資基準日。

上述現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數之 13.5%由員工認購，其餘之 86.5%計 346,000 仟股，依力積電公司原股東力晶公司 108 年度股東常會決議將其認購權利讓與力晶公司全體股東。

力積電公司經 108 年 12 月 24 日董事會決議發行員工認股權憑證 150,000 仟單位，每單位認股權憑證得認購之股數為普通股 1 股。經金管會申報生效並核准發行，並於 109 年 1 月 20 日董事會決議第一階段發行員工認股權憑證 138,440 仟單位。

(二) 資本公積

	108年12月31日	107年12月31日
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)		
股票發行溢價	$170,680	$ 89,200
僅得用以彌補虧損		
員工認股權執行轉入之金額	11,247	-
	$181,927	$ 89,200

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利

依力積電公司 108 年 3 月 12 日修正後章程之盈餘分派政策規定，力積電公司盈餘分派或虧損彌補得於每半會計年度終了後為之。每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達力積電公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後之。力積電公司章程規定之員工及董監事酬勞分派政策，參閱附註二一之(七)員工酬勞及董監事酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

力積電公司於 108 年 4 月 12 日及 107 年 5 月 10 日董事會（代行股東會職權），分別決議通過 107 及 106 年度盈餘分配案如下：

盈餘分配表

	107年度	106年度
法定盈餘公積	$ 98,593	$ 58,115
現金股利	95,234	-
股票股利	857,109	523,032
每股現金股利（元）	0.27	-
每股股票股利（元）	2.39	1.71

力積電公司於 109 年 3 月 9 日董事會擬議虧損撥補案，尚待預計於 109 年 5 月 27 日召開之股東常會決議。

(四) 其他權益項目

其他權益項目之變動數如下：

108 年度

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計
年初餘額	($ 4,316)	$ 356	($ 3,960)
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額	(294)	-	(294)
權益工具未實現評價損益	-	39,775	39,775
共同控制下後手由本公司業主權益轉出	4,316	(40,131)	(35,815)
年底餘額	($ 294)	$ -	($ 294)

107 年度

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計
年初餘額（國際會計準則第 39 號）	($ 4,127)	$ 53,136	$ -	$ 49,009
追溯適用國際財務報導準則第 9 號之影響數	-	(53,136)	(70,724)	(123,860)
調整後期初餘額（國際財務報導準則第 9 號）	(4,127)	-	(70,724)	(74,851)
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額	(189)	-	-	(189)
權益工具未實現評價損益	-	-	29,289	29,289
處分權益工具累計損益移轉至保留盈餘	-	-	41,791	41,791
年底餘額	($ 4,316)	$ -	$ 356	($ 3,960)

二十、營業收入

	108年度	107年度
客戶合約收入		
商品銷售收入	$ 35,897,121	$ 49,913,779

(一) 合約餘額

	108年12月31日	107年12月31日	107年1月1日
應收帳款（附註八）	$ 5,394,884	$ 6,380,859	$ 5,365,698
合約負債			
商品銷售	$ 808,913	$ 1,138,000	$ 528,081
其　　他	117,446	117,598	44,316
	$ 926,359	$ 1,255,598	$ 572,397

來自年初合約負債以及前期已滿足之履約義務於當期認列為收入之金額如下：

	108年度	107年度
來自年初合約負債		
銷貨商品	$715,386	$438,410
其他（帳列其他收益及費損淨額）	46,922	32,866
	$762,308	$471,276

(二) 客戶合約收入之細分

商品銷貨收入依主要產品項目細分

	108年度	107年度
主要地區市場		
台　　灣	$23,480,915	$30,730,668
中　　國	2,223,105	3,173,691
日　　本	1,487,232	3,808,830
其　　他	8,705,869	12,200,590
	$35,897,121	$49,913,779
產品項目		
包裝元件	$ 382,834	$ 216,922
晶　　圓	35,514,287	49,244,787
其　　他	-	452,070
	$35,897,121	$49,913,779

二一、本年度淨（損）利

(一) 其他收益及費損淨額

	108年度	107年度
賠償收入	$141,987	$ 2,412
處分及報廢不動產、廠房及設備淨益	950	15,983
其他收入及支出	29,748	239,612
	$172,685	$258,007

(二) 其他收入

	108年度	107年度
利息收入	$ 62,543	$ 91,954
股利收入	-	610
	$ 62,543	$ 92,564

(三) 其他利益及損失

	108年度	107年度
外幣兌換淨（損）益	($ 68,070)	$166,282
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨益（損）	12,784	(39,512)
	($ 55,286)	$126,770

(四) 財務成本

	108年度	107年度
借款之利息	$437,244	$405,859
租賃負債之利息	75,849	-
應付租賃款之利息	-	49,562
其　　他	10,270	10,462
	$523,363	$465,883

利息資本化相關資訊如下：

	108年度	107年度
利息資本化金額	$ 72,899	$ 58,746
利息資本化利率	1.84%~1.98%	1.85%~2.39%

(五) 折舊及攤銷

	108年度	107年度
不動產、廠房及設備	$ 4,680,293	$ 3,926,743
使用權資產	167,884	-
無形資產	331,836	332,231
合　　計	$ 5,180,013	$ 4,258,974
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	$ 4,521,636	$ 3,780,769
營業費用	326,254	145,063
其他收益及費用	287	911
	$ 4,848,177	$ 3,926,743

（接次頁）

（承前頁）

	108年度	107年度
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	$ 318,401	$ 318,772
營業費用	13,435	13,459
	$ 331,836	$ 332,231

(六) 員工福利費用

	108年度	107年度
退職後福利		
確定提撥計畫	$ 320,001	$ 308,063
確定福利計畫（附註十八）	27,217	44,644
	347,218	352,707
股份基礎給付		
權益交割	11,247	-
其他員工福利	7,709,766	11,538,893
員工福利費用合計	$ 8,068,231	$ 11,891,600
依功能別彙總		
營業成本	$ 5,298,929	$ 7,853,230
營業費用	2,769,302	4,038,370
	$ 8,068,231	$ 11,891,600

(七) 員工酬勞及董監事酬勞

力積電公司係以當年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之力積電公司稅前淨利，應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

108 年度係為稅前淨損，擬不估列員工酬勞及董監事酬勞。

107 年度員工酬勞及董監事酬勞於 108 年 2 月 12 日經董事會決議如下：

金　　額

	107年度	
	現　　金	股　　票
員工酬勞	$178,129	$ -
董監事酬勞	39,293	-

年度合併財務報表通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

107 及 106 年度員工酬勞及董監事酬勞之實際配發金額與 107 及 106 年度合併財務報告之認列金額並無差異。

二二、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅費用主要組成項目

	108年度	107年度
當期所得稅		
本年度產生者	$ 9,020	$ 46,859
未分配盈餘加徵	-	200,208
以前年度之調整	(1,321)	69,410
	7,699	316,477
遞延所得稅		
本年度產生者	536,517	(323,220)
稅率變動	-	(252,253)
與所得稅抵減有關	(515,917)	1,984,300
	20,600	1,408,827
認列於損益之所得稅費用	$ 28,299	$ 1,725,304

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	108年度	107年度
本年度稅前淨（損）利	($ 2,614,885)	$ 8,640,048
稅前淨（損）利按法定稅率計算之稅額	($ 528,445)	$ 2,683,201
調節項目之所得稅影響數		
決定課稅所得時不可計入之損益	15,729	103,875
遞延所得稅資產／負債之所得稅影響數	533,316	(1,064,326)
遞延所得稅資產／負債之稅率變動影響數	-	(275,006)
本年度產生者	9,020	6,426
未分配盈餘加徵	-	200,208
以前年度之調整	(1,321)	70,926
認列於損益之所得稅費用	$ 28,299	$ 1,725,304

我國於 107 年修正中華民國所得稅法，將營利事業所得稅稅率由 17%調整為 20%。該修正並規定 107 年度未分配盈餘所適用之稅率將由 10%調降為 5%。

(二) 本期所得稅資產與負債

	108年12月31日	107年12月31日
本期所得稅資產		
應收退稅款	$ 11,878	$ 7,218
本期所得稅負債		
應付所得稅	$ 108	$200,706

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

108 年度

	年初餘額	共同控制下前手權益轉出數	認列於損益	年底餘額
遞延所得稅資產				
虧損扣抵	$ 10,804,272	($ 10,739,917)	$ 415,210	$ 479,565
暫時性差異				
折舊	56,831	-	72,592	129,423
備抵存貨跌價損失	178,992	(176,029)	246,216	249,179
其他	1,115,579	(1,083,405)	290,920	323,094
備抵評價	(10,374,964)	10,322,749	(508,460)	(560,675)
	$ 1,780,710	($ 1,676,602)	$ 516,478	$ 620,586
遞延所得稅負債				
暫時性差異				
不動產、廠房及設備	$ 1,752,678	($ 1,671,567)	$ 526,685	$ 607,796
其他	7,432	(5,035)	10,393	12,790
	$ 1,760,110	($ 1,676,602)	$ 537,078	$ 620,586

107 年度

	年初餘額	認列於損益	年底餘額
遞延所得稅資產			
虧損扣抵	$ 12,255,301	($ 1,451,029)	$ 10,804,272
暫時性差異			
折舊	111,725	(54,894)	56,831
備抵存貨跌價損失	77,459	101,533	178,992
其他	1,795,960	(680,381)	1,115,579
備抵評價	(11,039,633)	664,669	(10,374,964)
	$ 3,200,812	($ 1,420,102)	$ 1,780,710
遞延所得稅負債			
暫時性差異			
不動產、廠房及設備	$ 1,753,663	($ 985)	$ 1,752,678
其他	17,722	(10,290)	7,432
	$ 1,771,385	($ 11,275)	$ 1,760,110

(四) 未於合併資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異及未使用虧損扣抵金額

	108年12月31日	107年12月31日
虧損扣抵金額	$ -	$45,118,730
可減除暫時性差異金額	$ 705,104	$ 6,756,089

(五) 未使用之虧損扣抵及免稅相關資訊

截至 108 年 12 月 31 日止，虧損扣抵相關資訊如下：

尚未扣抵餘額	最後扣抵年度
$ 2,397,828	118 年度

(六) 所得稅核定情形

力積電公司截至 106 年度以前之營利事業所得稅申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二三、每股（虧損）盈餘

單位：每股元

	108年度	107年度
基本每股（虧損）盈餘	($ 0.94)	$ 2.56
稀釋每股（虧損）盈餘	($ 0.94)	$ 2.54

計算每股（虧損）盈餘時，依附註一所述本公司於 108 年 5 月 1 日進行母子間組織重組，並由力積電公司發行新股予力晶公司作為收購之對價，係屬共同控制下之組織重組，應視為自始即已合併而追溯前期股數。另力積電公司無償配股之影響業已追溯調整，該無償配股基準日訂於 108 年 4 月 22 日，因追溯調整，107 年度之基本及稀釋每股盈餘變動如下：

單位：每股元

	追溯調整前	追溯調整後
基本每股盈餘	$ 2.75	$ 2.56
稀釋每股盈餘	$ 2.64	$ 2.54

用以計算每股（虧損）盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨（損）利

	108年度	107年度
歸屬於本公司業主之淨（損）利	($1,480,370)	$ 985,928
歸屬於共同控制下前手權益淨（損）利	(1,162,814)	5,890,576
歸屬於共同控制下後手權益淨損（利）	-	38,240
用以計算基本及稀釋每股(虧損）盈餘之淨（損）利	($2,643,184)	$6,914,744

股　　數　　單位：仟股

	108年度	107年度
用以計算基本每股（虧損）盈餘之普通股加權平均股數	2,821,863	2,705,197
具稀釋作用潛在普通股之影響：員工酬勞	-	18,388
用以計算稀釋每股（虧損）盈餘之普通股加權平均股數	2,821,863	2,723,585

若力積電公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

本公司員工酬勞若採發放股票方式，因具反稀釋作用，故未納入稀釋每股虧損之計算。

二四、股份基礎給付協議

現金增資保留員工認股

力積電公司經董事會決議現金增資發行新股，並於 108 年 6 月 28 日經董事會決議調整最終發行股數及募集金額，並依據公司法保留新股總數 13.5%計 54,000 仟股由員工認購。員工認購不足一股之畸零股或放棄認股之股份，則授權董事長洽特定人認購之。

力積電公司於 108 年 7 月 16 日給與之員工認股權，其公平價值使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之參數如下：

衡量日每股股權公平價值	$ 9.89
行使價格	10.10
預期波動率	30.58%
預期存續期間	0.062 年
預期股利率	0.00%
無風險利率	0.48%
認股權公平價值	0.2083

力積電公司 108 年度因現金增資保留員工認購權利認列之酬勞成本為 11,247 仟元。

二五、資本風險管理

本公司進行資本管理係確保公司能夠於繼續經營之前提下，藉由調整債務與權益最適化，以達成股東權益極大化。

本公司資本結構係由本公司之淨債務（即借款減除現金及約當現金）及歸屬於母公司業主之權益（即股本、資本公積、保留盈餘及其他權益項目）組成。

二六、金融工具

(一) 公允價值之資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

108 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 4,372	$ -	$ 4,372
透過損益按公允價值衡量之金融負債				
衍生工具	$ -	$ -	$ -	$ -

107 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 7,151	$ -	$ 7,151
透過損益按公允價值衡量之金融負債				
衍生工具	$ -	$ 81	$ -	$ 81

108 及 107 年度無第 1 等級與第 2 等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 金融工具以第 3 等級公允價值衡量之調節

107 年度

金融資產	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 權益工具
年初餘額	$ 14,869
認列於其他綜合損益(透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益)	2,892
本年度處分	(17,761)
年底餘額	$ -

3. 第 2 等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具－遠期外匯合約	現金流量折現法：按期末之可觀察遠期匯率及合約所訂匯率估計未來現金流量，並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

4. 第 3 等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

國內未上市（櫃）權益投資係採淨市場法，係以可類比標的之交易價格為依據，依據標的公司及市場同業之財務資料，以市場乘數例如本益比、股價淨值比、股價營收比或其他財務比率來分析評價。

(三) 金融工具之種類

	108年12月31日	107年12月31日
金融資產		
強制透過損益按公允價值衡量	$ 4,372	$ 7,151
按攤銷後成本衡量之金融資產（註1）	11,925,267	15,788,219
金融負債		
透過損益按公允價值衡量持有供交易	-	81
按攤銷後成本衡量（註2）	39,593,407	32,444,850

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款－非關係人淨額、應收帳款－關係人淨額、其他應收款、其他金融資產及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含短期借款、應付帳款－非關係人、應付設備款、其他應付款、一年內到期之長期借款、租賃負債、長期借款及存入保證金等以攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

本公司之財務風險管理目標，係為管理與營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本公司致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司對於前述財務風險管理已依相關規範建立適當之政策、程序及內部控制，重要財務活動須經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。公司恪遵相關財務操作程序。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）及利率變動風險（參閱下述(2)）。本公司從事衍生金融工具（包括遠期外匯）以管理所承擔之外幣匯率。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而產生匯率變動風險。本公司匯率風險之管理採部分自然避險，並於政策許可之範圍內，利用遠期外匯合約管理風險。本公司之匯率風險管理，以避險為目的，不以獲利為目的。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目），參閱附註三一。

敏感度分析

本公司主要受到美金、日幣、歐元及人民幣匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少 1%時，本公司之敏感度分析。敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其期末之換算以匯率變動 1%予以調整。敏感度分析之範圍包括現金及約當現金、應收帳款（含關係人）、其他應收款、應付帳款、應付設備款、租賃負債、其他應付款及借款。下表之正數係表示當新台幣相對於各相關貨幣貶值 1%時，將使稅前淨利增加之金額；當新台幣相對於各相關貨幣升值 1%時，其對稅前淨利之影響將為同金額之負數。

	美金之影響		日幣之影響		歐元之影響		人民幣之影響	
	108年度	107年度	108年度	107年度	108年度	107年度	108年度	107年度
損益	$ 19,917	$ 36,476	($ 2,249)	($ 2,322)	($ 2,863)	($ 2,866)	$ 130	$ 417

(2) 利率風險

因本公司內個體同時以固定及浮動利率借入資金，因而產生利率暴險。本公司定期評估避險活動，以確保採用最符合成本效益之避險策略。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	108年12月31日	107年12月31日
具公允價值利率風險		
一金融資產	$ 4,008,226	$ 5,568,852
一金融負債	(5,164,169)	(1,294,320)
具現金流量利率風險		
一金融資產	2,044,064	3,166,763
一金融負債	(25,809,962)	(19,410,840)

敏感度分析

有關利率風險之敏感性分析，主要針對資產負債表日浮動利率金融負債之現金流量變動為計算基礎。

若利率增加／減少 0.1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 108 及 107 年度之稅前淨利將分別減少／增加 23,766 仟元及 16,244 仟元，主因為本公司之浮動利率淨負債利率暴險。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成集團財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務及本公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於資產負債表所認列之金融資產帳面金額。

為減輕信用風險，本公司已訂定授信及應收帳款管理辦法，以確保應收帳款之收回，以及逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司會每季逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。

本公司應收帳款之對象涵蓋眾多客戶，分散於不同產業及地理區域。本公司持續地針對應收帳款客戶之財務狀況每年或不定期進行評估。

個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、信評機構評等、本公司內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。本公司定期或不定期

針對應收帳款客戶之財務狀況進行評估，必要時亦會要求客戶提供預收貨款、產能保證金、質押定存或其他擔保品，以降低特定客戶的信用風險。

另因流動資金及衍生金融工具之交易對方係信用良好之銀行，故該信用風險係屬有限。

3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應集團營運並減輕現金流量波動之影響。

銀行借款對本公司而言係為一項主要流動性風險來源。截至 108 年及 107 年 12 月 31 日止，本公司未動用之融資額度參閱下列(3)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依本公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。因此，本公司可被要求立即還款之銀行借款，係列於下表最早之期間內，不考慮銀行立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

108 年 12 月 31 日

	1 年 以 下	1 ～ 5 年	5 年 以 上	合 計
非衍生金融負債				
無附息負債	$ 8,319,408	$ -	$ -	$ 8,319,408
租賃負債	301,111	2,452,181	2,480,436	5,233,728
浮動利率工具	5,539,868	19,414,805	923,800	25,878,473
固定利率工具	15,575	880,833	-	896,408
	$14,175,962	$22,747,819	$ 3,404,236	$40,328,017

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1 年 以 內	1 ～ 5 年	5 ～ 1 0 年	1 0 ～ 1 5 年	1 5 ～ 2 0 年	2 0 年 以 上
租賃負債	$ 301,111	$ 2,452,181	$ 1,361,842	$ 481,923	$ 442,115	$ 194,556

107 年 12 月 31 日

	0 ～ 3 個 月	4 ～ 6 個 月	7個月～1年	1 ～ 5 年	5 年 以 上	合 計
非衍生金融負債						
無附息負債	$ 8,808,287	$ 2,460,985	$ 552,964	$ -	$ -	$11,822,236
浮動利率工具	1,103,809	1,103,809	1,786,785	12,902,614	2,580,000	19,477,017
固定利率工具	250,000	-	1,063,530	-	-	1,313,530
	$10,162,096	$ 3,564,794	$ 3,403,279	$12,902,614	$ 2,580,000	$32,612,783

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

(2) 衍生金融負債之流動性及利率風險表

針對衍生金融工具之流動性分析，就採淨額交割之衍生工具而言，係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製；就採總額交割之衍生工具而言，係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。

108 年 12 月 31 日

	0～3個月	4～6個月	7個月～1年	1至5年	5年以上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流　出	($ 565,342)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流　入	569,714	-	-	-	-
	$ 4,372	$ -	$ -	$ -	$ -

107 年 12 月 31 日

	0～3個月	4～6個月	7個月～1年	1至5年	5年以上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流　出	($1,928,637)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流　入	1,935,707	-	-	-	-
	$ 7,070	$ -	$ -	$ -	$ -

(3) 融資額度

	108年12月31日	107年12月31日
無擔保金融業及非金融業透支額度		
一已動用金額	$ 525,000	$ 2,102,654
一未動用金額	2,300,000	1,200,000
	$ 2,825,000	$ 3,302,654
有擔保金融業及非金融業透支額度		
一已動用金額	$26,150,262	$18,602,506
一未動用金額	2,466,000	13,593,800
	$28,616,262	$32,196,306

二七、關係人交易

本公司及子公司（係本公司之關係人）間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時全數予以銷除，故未揭露於本附註。除已於其他附註揭露外，本公司與其他關係人間之交易如下。

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
力晶公司	本公司之母公司
黃 崇 仁	主要管理階層
蔡 國 智	主要管理階層
力旺電子股份有限公司	實質關係人（力晶公司 107 年 5 月 24 日董監事改選後為非關係人）
力積電子股份有限公司	實質關係人(力積電公司 107 年 9 月 4 日董監事改選後為非關係人）
優立有限公司	實質關係人（108 年 8 月 14 日起為非關係人）
智安電子股份有限公司	實質關係人(107 年 12 月 24 日董監事改選後為非關係人）
力智電子股份有限公司	實質關係人（107 年 6 月 11 日董監事改選後為非關係人）
力祥半導體股份有限公司	實質關係人（107 年 6 月 11 日董監事改選後為非關係人）
愛普科技股份有限公司	實質關係人(力積電公司 107 年 9 月 4 日董監事改選後為非關係人）
智旺科技股份有限公司	實質關係人
智立投資股份有限公司	實質關係人
智豐科技股份有限公司	實質關係人
台灣光罩股份有限公司	實質關係人
黃 毓 秀	實質關係人
財團法人力晶文化基金會	實質關係人
力新國際科技股份有限公司	實質關係人
Zentel Japan Corporation	實質關係人
Powerchip Corporation Japan	實質關係人
智仁科技開發股份有限公司	關聯企業
力信投資股份有限公司	關聯企業
世仁投資股份有限公司	關聯企業
智典國際股份有限公司	關聯企業
世成科技股份有限公司	關聯企業
智成電子股份有限公司	關聯企業
合肥晶合集成電路有限公司	關聯企業

(二) 營業收入

	108年度	107年度
實質關係人	$ 1,656,474	$ 5,712,105
關聯企業	214	-
	$ 1,656,688	$ 5,712,105

(三) 進　　貨

	108年度	107年度
母公司	$ 1,353	$ -

(四) 出售存貨及設備維修備品

	108年度	107年度
關聯企業	$ -	$ 126

(五) 銷貨成本－權利金

	108年度	107年度
實質關係人	$ -	$ 31,351
關聯企業	18,900	62,399
	$ 18,900	$ 93,750

(六) 製造費用

	108年度	107年度
實質關係人	$ 340	$ 168

(七) 管理費用

	108年度	107年度
主要管理階層	$ -	$ 84
實質關係人	5,868	66,574
關聯企業	581	13,909
	$ 6,449	$ 80,567

(八) 研發費用

	108年度	107年度
實質關係人	$ 206	$ 2,702
關聯企業	101,712	101,661
	$101,918	$104,363

(九) 其他收益及費損淨額

	108年度	107年度
主要管理階層	$ 1	$ -
實質關係人	7,548	15,791
關聯企業	1,637	88,978
	$ 9,186	$104,769

(十) 應收帳款

	108年12月31日	107年12月31日
實質關係人	$ 49,914	$129,542

(十一) 其他應收款

	108年12月31日	107年12月31日
關聯企業	$ -	$ 61,645

(十二) 向關係人借款（帳列短期借款）:

	108年12月31日	107年12月31日
關聯企業	$ -	$489,435

財務成本

	108年度	107年度
關聯企業	$ 1,641	$ 16,871

本公司向關係人借款之借款利率於 107 年 12 月 31 日為 2.50%。上列借款皆為無擔保借款。

(十三) 其他應付款

	108年12月31日	107年12月31日
主要管理階層	$ 2,201	$ -
實質關係人	84	327
關聯企業	114,988	137,907
	$117,273	$138,234

(十四) 合約負債

	108年12月31日	107年12月31日
實質關係人	$ -	$ 235
關聯企業	-	59,970
	$ -	$ 60,205

(十五) 存出保證金

	108年12月31日	107年12月31日
主要管理階層	$ 1	$ 1
實質關係人	1	1
	$ 2	$ 2

(十六) 存入保證金

	108年12月31日	107年12月31日
實質關係人	$ -	$ 414
關聯企業	-	226
	$ -	$ 640

本公司與關係人間晶圓代工之銷貨價格，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司支付關係人之權利金，本公司與關係人之進貨價格、存貨及設備維修備品出售，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人之製造費用、管理費用及研發費用係依雙方議定之合作協議，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人間之其他收益及費損，係依據雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

上述之其他應收關係人款項主要係服務收入產生。

上述之其他應付關係人款項主要係權利金費用及技術開發費產生。

本公司合約負債之銷貨條件，係與客戶交易時參考市場行情，議定價格及數量。

本公司與關係人收取之存入保證金，主要係押金。

除上述交易外，本公司與其他關係人間之交易，係按一般交易條件及價格辦理。

(十七) 承租協議

關係人類別／名稱	108年度	107年度
取得使用權資產		
實質關係人	$ 4,946	$ -

帳列項目	關係人類別／名稱	108年12月31日
租賃負債－流動	主要管理階層	$ 80
	實質關係人	2,619
	關聯企業	6,911
		$ 9,610
租賃負債－非流動	主要管理階層	$ 245
	實質關係人	1,916
	關聯企業	21,100
		$ 23,261

帳列項目	關係人類別／名稱	108年度
財務成本	主要管理階層	$ 9
	實質關係人	51
	關聯企業	898
		$ 958

帳列項目	關係人類別／名稱	107年度
租賃費用	主要管理階層	$ 84
	實質關係人	6,495
	關聯企業	12,844
		$ 19,423

本公司向關係人承租辦公室、停車位及公務車，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金按月支付。

(十八) 主要管理階層薪酬

108 及 107 年度對董事及其他主要管理階層之薪酬總額如下：

	108年度	107年度
短期員工福利	$ 160,996	$ 1,064,259
退職後福利	22,723	-
	$ 183,719	$ 1,064,259

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、質抵押之資產

本公司下列資產已提供作為長期借款、天然氣使用、承租科管局土地及保稅品出區之擔保品：

	108年12月31日	107年12月31日
不動產、廠房及設備	$ 27,454,063	$ 20,023,645
受限制存款（帳列其他金融資產）	1,896,531	1,624,879
	$ 29,350,594	$ 21,648,524

二九、重大或有負債及未認列之合約承諾

除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

(一) 力積電公司分別於 92 年 8 月、94 年 3 月、97 年 6 月、99 年 3 月、10 月、100 年 7 月及 102 年 7 月與 Micron Memory Japan, Inc.（原 Elpida Memory Inc.）簽署若干動態隨機存取記憶體技術移轉與授權合約，力積電公司承諾自技術移轉完成後 5 年內支付一定金額之技術授權費及依約定產品之售價給付一定比例之權利金。惟雙方另於 100 年 5 月及 102 年 7 月簽署合作協議，修訂權利金支付比例。

(二) 力積電公司分別於 92 年 8 月及 94 年 3 月與某公司簽署若干動態隨機存取記憶體技術之專利授權合約，力積電公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(三) 力積電公司於 92 年 8 月與某公司等簽署若干動態隨機存取記憶體之專利技術授權合約，力積電公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(四) 力積電公司與某公司簽訂長期矽原料進貨合約，以確保矽原料穩定供貨，其中約定力積電公司須購買之相關最低數量及價格。

(五) 力積電公司於 108 年 7 月與愛爾蘭商遠東金士頓公司簽訂代工合約至 110 年 10 月 31 日止，力積電公司承諾以約定價格為其製造記憶體產品。

(六) 力積電公司與客戶 Mitsubishi Electric Corporation 簽訂晶圓製造合約，其中針對晶圓製造的部分機器設備，係由該公司提供，力積電公司需負保管及使用之責。

前述(一)至(四)之權利義務於收購轉讓基準日(即 108 年 5 月 1 日)由力晶公司轉讓予力積電公司。

三十、其　　他

本公司為重整集團組織架構，依附註一所述交易因屬共同控制下之組織重組，應視為自始即已合併而追溯重編前期比較財務報表。

經重編 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表及 107 年度之合併綜合損益表，其影響如下：

合併資產負債表

	107年12月31日		
會　計　項　目	重編前金額	影響金額	重編後金額
資　產			
流動資產	$ 3,601,769	$ 18,890,865	$ 22,492,634
非流動資產	8,316,719	36,939,248	45,255,967
資產總計	$ 11,918,488	$ 55,830,113	$ 67,748,601
負債及權益			
流動負債	$ 3,952,307	$ 14,875,144	$ 18,827,451
非流動負債	3,068,742	15,891,601	18,960,343
負債總計	$ 7,021,049	$ 30,766,745	$ 37,787,794
權　益			
股　本	$ 3,586,674	$ -	$ 3,586,674
資本公積	89,200	-	89,200
保留盈餘	1,190,499	-	1,190,499
其他權益	(3,960)	-	(3,960)
本公司業主之權益	4,862,413	-	4,862,413
共同控制下前手權益	-	25,295,906	25,295,906
共同控制下後手權益	-	(197,512)	(197,512)
非控制權益	35,026	(35,026)	-
權益總計	4,897,439	25,063,368	29,960,807
負債與權益總計	$ 11,918,488	$ 55,830,113	$ 67,748,601

合併綜合損益表

會計項目	107年度 重編前金額	影響金額	重編後金額
營業收入	$ 7,637,449	$ 42,276,330	$ 49,913,779
營業成本	5,637,731	28,995,783	34,633,514
營業費用	1,613,386	5,038,289	6,651,675
其他收益及費損淨額	682,240	(424,233)	258,007
營業外收入及支出	8,477	(255,026)	(246,549)
所得稅費用	106,424	1,618,880	1,725,304
本期淨利（註）	970,625	5,944,119	6,914,744
其他綜合損益	12,552	(24,595)	(12,043)
本期綜合損益總額（註）	$ 983,177	$ 5,919,524	$ 6,902,701

註：重編前淨利包含歸屬母公司業主權益及非控制權益分別為985,928 仟元及(15,303)仟元；重編前綜合損益總額包含歸屬母公司業主權益及非控制權益分別為 998,480 仟元及(15,303)仟元。

三一、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本公司各合併功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債資訊如下：

	108年12月31日 外幣	匯率	新台幣	107年12月31日 外幣	匯率	帳面價值
外幣資產						
貨幣性項目						
美金	$ 225,938	30.046	$6,788,536	$ 229,049	30.73	$7,038,687
歐元	60	33.66	2,006	277	35.21	9,738
日幣	1,594,271	0.2766	440,975	1,511,665	0.2783	420,696
人民幣	3,006	4.31	12,955	9,301	4.48	41,670
外幣負債						
貨幣性項目						
美金	159,650	30.046	4,796,840	110,351	30.73	3,391,089
歐元	8,565	33.66	288,290	8,416	35.21	296,311
日幣	2,407,362	0.2766	665,876	2,346,177	0.2783	652,941

本公司主要承擔美金及新台幣之外幣匯率風險。以下資訊係按持有外幣合併之功能性貨幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等功能性貨幣換算至表達貨幣之匯率。具重大影響之外幣兌換損益（已實現及未實現）如下：

功能性貨幣	108年度 功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益	107年度 功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益
新台幣	1(新台幣：新台幣)	($ 68,070)	1(新台幣：新台幣)	$ 166,282

三二、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊：

1. 資金貸與他人。(無)
2. 為他人背書保證。(無)
3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)。(無)
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上。(無)
5. 取得不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上。(無)
6. 處分不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上。(無)
7. 與關係人進、銷貨之金額達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。(附表一)
8. 應收關係人款項達新臺幣1億元或實收資本額20%以上。(無)
9. 從事衍生工具交易。(本公司從事衍生性商品相關資訊請參閱附註七及二六)
10. 被投資公司資訊、所在地區…等相關資訊。(附表二)
11. 其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額。(附表三)

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。(無)
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益。(無)

三三、部門資訊

力積電公司及子公司之營運決策者用以分配資源及評量部門績效係著重於產品銷售之財務資訊，而每一產品皆具有相類似之經濟特性，每一產品使用類似之製程以生產類似之產品，且透過統一集中之銷售方式銷售，故力積電公司及子公司彙總為單一營運部門報導。另力積電公司及子公司提供給營運決策者複核之部門資訊，其衡量基礎與財務報表相同，故 108 及 107 年度應報導之部門收入及營運結果可參照 108 及 107 年度之合併綜合損益表；108 年及 107 年 12 月 31 日應報導之部門資產可參照 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表。

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

與關係人進、銷貨交易金額達新台幣1億元或實收資本額20%以上

民國108年1月1日至12月31日

附表一

單位：新台幣仟元

進（銷）貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收（付）票據、帳款		備註
			進／銷貨	金額	佔總進／銷貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率	
力積電公司	智豐科技股份有限公司	實質關係人	銷貨	$ 1,605,063	4.47%	註1	$ -	—	$ -	-	註2

註1： 主要係月結60天付款。

註2： 本公司為重整集團組織架構，於108年5月1日收購母公司力晶公司晶圓相關業務，故銷貨金額係包含108年5月1日前力晶公司銷售予智豐科技股份有限公司之金額。

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

被投資公司資訊、所在地區...等相關資訊

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表二

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數（仟股）	比率（%）	帳面金額			
力積電公司	Global Powertec Co., Ltd.	英屬維京群島	從事各式投資業務	$ 1	$ 1	-	100.00	($ 57,439)	($ 15,184)	($ 15,184)	註 1
Global Powertec Co., Ltd.	Power Memory Inc.	日本	從事半導體及電子零組件之開發及販售	703,165	703,165	500	100.00	10,233	1,387	1,387	-
	Maxram Inc.	日本	從事半導體及電子零組件之開發及販售	22,415	-	800	100.00	5,464	(16,716)	(16,716)	註 2

註 1： 本公司為重整集團組織架構，於 108 年 5 月 1 日由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec 公司依企業併購法讓與力積電公司。

註 2： Global Powertec 公司於 108 年 3 月 22 日取得該公司 100%之股權。

力晶積成電子製造有限公司及子公司

母子公司間及各子公司業務關係及重要交易往來情形

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表三

單位：新台幣仟元

交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係（註1）	交易往來情形			
			科目	金額（註3）	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率
力積電公司	PowerMemory 公司	1	研發費用	$ 98,945	註 2	-

註 1： 1 係代表母公司對子公司之交易。

註 2： 係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

註 3： 本公司為重整集團組織架構，於 108 年 5 月 1 日收購母公司力晶公司晶圓相關業務，故研發費用金額係包含 108 年 5 月 1 日前力晶公司與 PowerMemory 公司交易往來之金額。

【附件二】

一〇九年度合併財務報告暨會計師查核報告

股票代碼：6770

力晶積成電子製造股份有限公司
及子公司

合併財務報告暨會計師查核報告

民國 109 及 108 年度

地址：新竹科學工業園區新竹市力行一路18號

電話：(03)579-5000

§目　　錄§

項目	頁次	財務報告附註編號
一、封　　面	1	-
二、目　　錄	2	-
三、關係企業合併財務報告聲明書	3	-
四、會計師查核報告	4～7	-
五、合併資產負債表	8	-
六、合併綜合損益表	9～10	-
七、合併權益變動表	11	-
八、合併現金流量表	12～13	-
九、合併財務報告附註		
(一) 公司沿革	14	一
(二) 通過財務報告之日期及程序	14	二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	15～17	三
(四) 重大會計政策之彙總說明	17～28	四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	28～29	五
(六) 重要會計科目之說明	29～62	六～二六
(七) 關係人交易	62～67	二七
(八) 質抵押之資產	67	二八
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	67	二九
(十) 其　　他	-	-
(十一) 重大之災害損失	-	-
(十二) 重大之期後事項	-	-
(十三) 具重大影響之外幣資產及負債資訊	68	三十
(十四) 附註揭露事項		
1. 重大交易事項相關資訊	68～69、71～74	三一
2. 轉投資事業相關資訊	68～69、71～74	三一
3. 大陸投資資訊	69	三一
4. 主要股東資訊	69、75	三一
(十五) 部門資訊	69～70	三二

關係企業合併財務報告聲明書

本公司109年度（自109年1月1日至109年12月31日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：力晶積成電子製造股份有限公司

董事長：黃　崇　仁

中　華　民　國　110　年　3　月　9　日

會計師查核報告

力晶積成電子製造股份有限公司　公鑒：

查核意見

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與力晶積成電子製造股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之真實性

由於收入認列具有顯著風險。本會計師認為力晶積成電子製造股份有限公司及子公司銷貨收入之交易存有真實性風險，故於本年度將主要銷售客戶之收入真實性認定為關鍵查核事項。

本會計師對此之查核程序包括：

1. 瞭解及測試收入認列之主要內部控制設計及執行之有效性。
2. 抽核並檢視銷售客戶其背景資料之真實性，並瞭解對其授信條件之合理性。
3. 針對銷貨收入選取樣本抽核，檢視經交易對象確認之訂單、出貨單及發票等文件，以確認銷貨收入真實性，並核對銷貨對象及現金收款對象是否異常。
4. 複核銷貨收入是否有重大異常期後銷貨退回及折讓之情事，以確認收入認列之合理性。

其他事項

力晶積成電子製造股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估力晶積成電子製造股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算力晶積成電子製造股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對力晶積成電子製造股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使力晶積成電子製造股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致力晶積成電子製造股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於力晶積成電子製造股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責

查核案件之指導、監督及執行，並負責形成力晶積成電子製造股份有限公司及子公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

強調事項

如合併財務報告附註一及十所述，力晶積成電子製造股份有限公司於民國 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶科技股份有限公司全部或主要之相關營業，並由力晶積成電子製造股份有限公司發行新股予母公司力晶科技股份有限公司做為收購之對價，及由母公司力晶科技股份有限公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.讓與力晶積成電子製造股份有限公司；與民國 108 年 4 月 1 日由力晶積成電子製造股份有限公司將持股 100%之富碩投資股份有限公司及 Sprout International Limited 全數出售予母公司力晶科技股份有限公司。前述交易係屬共同控制下之組織重組，是以應追溯視為自始取得或除列，並重編比較期間之合併財務報告。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　黃　裕　峰　　會計師　鍾　鳴　遠

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中　華　民　國　110　年　3　月　9　日

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併財務報告

民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	109年12月31日 金額	%	108年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二六）	$ 6,421,984	8	$ 4,171,645	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二六）	6,798	-	4,372	-
1170	應收帳款－非關係人淨額（附註四、八及二六）	5,981,210	8	5,344,970	7
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、八、二六及二七）	253,494	-	49,914	-
1200	其他應收款（附註四及二六）	241,097	-	454,119	-
130X	存貨（附註四、九及二七）	7,818,611	10	6,385,497	9
1410	預付款項	379,415	1	661,675	1
1476	其他金融資產－流動（附註四、六、二六及二八）	567,931	1	536,531	1
1479	其他流動資產－其他	57,255	-	192,217	-
11XX	流動資產總計	21,727,795	28	17,800,940	24
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、十四、二四、二七及二八）	47,218,447	60	47,362,848	65
1755	使用權資產（附註四、五、十二及二七）	7,182,770	9	4,393,945	6
1780	無形資產（附註四及十三）	256,741	-	241,820	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	1,026,371	1	620,586	1
1915	預付設備款（附註二四）	90,063	-	1,540,275	2
1920	存出保證金（附註四、二六及二七）	7,687	-	8,088	-
1980	其他金融資產－非流動（附註四、六、二六及二八）	1,325,000	2	1,360,000	2
1990	其他非流動資產－其他（附註二四）	79,159	-	51,152	-
15XX	非流動資產總計	57,186,238	72	55,578,714	76
1XXX	資產總計	$ 78,914,033	100	$ 73,379,654	100

代碼	負債及權益	109年12月31日 金額	%	108年12月31日 金額	%
	流動負債				
2130	合約負債－流動（附註四、十九及二七）	$ 701,243	1	$ 926,359	1
2170	應付帳款－非關係人（附註二六）	2,641,535	3	2,583,447	4
2213	應付設備款（附註二四及二六）	1,574,291	2	1,797,230	2
2219	其他應付款（附註十五、二六及二七）	4,210,771	5	3,747,731	5
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	300	-	108	-
2280	租賃負債－流動（附註四、五、十二、二四、二六及二七）	354,050	1	215,566	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十四、二四、二六及二八）	7,065,983	9	5,512,049	8
2399	其他流動負債－其他（附註十六、二四及二六）	1,089,901	1	1,079,733	1
21XX	流動負債總計	17,638,074	22	15,862,223	21
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十四、二四、二六、二七及二八）	16,746,018	21	21,163,213	29
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	2,008,828	3	620,586	1
2580	租賃負債－非流動（附註四、五、十二、二四、二六及二七）	6,659,024	8	4,083,303	6
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	1,401,939	2	1,444,727	2
2645	存入保證金（附註二四及二六）	1,242,461	2	329,221	-
25XX	非流動負債總計	28,058,270	36	27,641,050	38
2XXX	負債總計	45,696,344	58	43,503,273	59
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及十八）				
3110	普通股股本	31,051,965	39	31,051,965	43
3200	資本公積	403,616	1	181,927	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	66,806	-	238,155	-
3350	未分配盈餘	1,695,690	2	(1,595,372)	(2)
3300	保留盈餘總計	1,762,496	2	(1,357,217)	(2)
3400	其他權益	(380)	-	(294)	-
3500	庫藏股票	(8)	-	-	-
31XX	本公司業主之權益總計	33,217,689	42	29,876,381	41
3XXX	權益總計	33,217,689	42	29,876,381	41
	負債及權益總計	$ 78,914,033	100	$ 73,379,654	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘（虧損）為元

代碼		109年度 金額	109年度 %	108年度 金額	108年度 %
4000	營業收入淨額（附註四、十九及二七）	$ 45,684,615	100	$ 35,897,121	100
5000	營業成本（附註四、九、二十及二七）	34,692,204	76	32,896,453	92
5900	營業毛利	10,992,411	24	3,000,668	8
	營業費用（附註二十及二七）				
6100	推銷費用	335,218	1	300,790	1
6200	管理費用	1,890,511	4	2,008,972	6
6300	研究發展費用	3,234,765	7	2,962,370	8
6000	營業費用合計	5,460,494	12	5,272,132	15
6500	其他收益及費損淨額（附註二十及二七）	212,327	-	172,685	1
6900	營業淨利（損）	5,744,244	12	(2,098,779)	(6)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二十）	27,977	-	62,543	-
7020	其他利益及損失（附註二十）	(294,965)	(1)	(55,286)	-
7050	財務成本（附註四、十四、二十及二七）	(678,183)	(1)	(523,363)	(2)
7000	營業外收入及支出合計	(945,171)	(2)	(516,106)	(2)
7900	稅前淨利（損）	4,799,073	10	(2,614,885)	(8)
7950	所得稅費用（附註四、五及二一）	(992,596)	(2)	(28,299)	-
8200	本年度淨利（損）	3,806,477	8	(2,643,184)	(8)

（接次頁）

（承前頁）

代碼		109年度 金額	109年度 %	108年度 金額	108年度 %
	其他綜合損益（附註四、十七及十八）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	($ 86,764)	-	($ 110,925)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(86)	-	(294)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(86,850)	-	(111,219)	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 3,719,627	8	($ 2,754,403)	(8)
	淨利（損）歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 3,806,477	8	($ 1,480,370)	(4)
8615	共同控制下前手權益	-	-	(1,162,814)	(3)
8600		$ 3,806,477	8	($ 2,643,184)	(7)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 3,719,627	8	($ 1,551,814)	(5)
8715	共同控制下前手權益	-	-	(1,162,814)	(3)
8715	共同控制下後手權益	-	-	(39,775)	-
8700		$ 3,719,627	8	($ 2,754,403)	(8)
	每股盈餘（虧損）（附註二二）				
9750	基本	$ 1.23		($ 0.94)	
9850	稀釋	$ 1.21		($ 0.94)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱垂源

力晶積[illegible]子公司

[illegible]

民國 109[illegible]2 月 31 日

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益（附註十八）														
										其他權益項目						
		股本		資本公積				保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	庫藏股票	總計	共同控制下前手權益	共同控制下後手權益	權益總計
		股數（仟股）	金額	股票發行溢價	受贈資產	員工認股權	合計	法定盈餘公積	未分配盈餘							
A1	108 年 1 月 1 日餘額	358,667	$ 3,586,674	$ 89,200	$ -	$ -	$ 89,200	$ 139,562	$ 1,050,937	($ 4,316)	$ 356	$ -	$ 4,862,413	$ 25,295,906	($ 197,512)	$ 29,960,807
	盈餘指撥及分配															
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	98,593	(98,593)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(95,234)	-	-	-	(95,234)	-	-	(95,234)
B9	本公司股東股票股利	85,711	857,109	-	-	-	-	-	(857,109)	-	-	-	-	-	-	-
D1	108 年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	(1,480,370)	-	-	-	(1,480,370)	(1,162,814)	-	(2,643,184)
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(110,925)	(294)	39,775	-	(71,444)	-	(39,775)	(111,219)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	(1,591,295)	(294)	39,775	-	(1,551,814)	(1,162,814)	(39,775)	(2,754,403)
N1	股份基礎給付交易	-	-	11,247	-	-	11,247	-	-	-	-	-	11,247	-	-	11,247
E1	現金增資	400,000	4,000,000	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	4,040,000	-	-	4,040,000
H3	組織重組	2,260,818	22,608,182	41,480	-	-	41,480	-	(4,078)	4,316	(40,131)	-	22,609,769	(24,593,842)	237,287	(1,746,786)
T1	前手權益於本年度分配員工酬勞轉列股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,750	-	460,750
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	3,105,196	31,051,965	181,927	-	-	181,927	238,155	(1,595,372)	(294)	-	-	29,876,381	-	-	29,876,381
	盈餘指撥及分配															
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	66,806	(66,806)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(600,000)	-	-	-	(600,000)	-	-	(600,000)
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	(238,155)	238,155	-	-	-	-	-	-	-
C3	因受領贈與產生者	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	(8)	-	-	-	-
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	3,806,477	-	-	-	3,806,477	-	-	3,806,477
D3	109 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(86,764)	(86)	-	-	(86,850)	-	-	(86,850)
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	3,719,713	(86)	-	-	3,719,627	-	-	3,719,627
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	221,681	221,681	-	-	-	-	-	221,681	-	-	221,681
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	3,105,196	$ 31,051,965	$ 181,927	$ 8	$ 221,681	$ 403,616	$ 66,806	$ 1,695,690	($ 380)	$ -	($ 8)	$ 33,217,689	$ -	$ -	$ 33,217,689

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱盈源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	$ 4,799,073	($ 2,614,885)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	5,852,409	4,848,177
A20200	攤銷費用	126,667	331,836
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨（利益）損失	(2,426)	2,698
A20900	財務成本	678,183	523,363
A21200	利息收入	(27,977)	(62,543)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	221,681	11,247
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(28,749)	(950)
A23700	存貨呆滯及跌價（回升利益）損失	(481,318)	350,932
A24100	外幣兌換淨利益	(302,357)	(74,269)
A29900	退款負債（迴轉）提列數	(1,000)	31,723
A29900	押金設算利息收入	50	54
A29900	押金設算利息費用	-	(1)
A29900	其　　他	(24)	(1,401)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款（含關係人）	(839,820)	899,396
A31180	其他應收款	281,372	36,449
A31200	存　　貨	(951,795)	7,346
A31230	預付款項	301,737	44,102
A31240	其他流動資產	134,962	(160,097)
A32125	合約負債	(135,620)	(140,971)
A32150	應付帳款	58,088	(432,539)
A32180	其他應付款	376,742	(1,858,056)
A32240	淨確定福利負債－非流動	(129,552)	(120,256)
A32230	其他流動負債	(320,896)	423,158
A33000	營運產生之淨現金流入	9,609,430	2,044,513
A33100	收取之利息	29,611	59,793
A33500	支付之所得稅	(862)	(39,505)
AAAA	營業活動之淨現金流入	9,638,179	2,064,801

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		109 年度	108 年度
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	($ 3,306,308)	($12,169,407)
B02800	處分不動產、廠房及設備	15,284	56,666
B03700	存出保證金增加	(1,430)	(1,209)
B03800	存出保證金減少	1,831	873
B04500	取得無形資產	(71,298)	(35,232)
B06500	其他金融資產減少（增加）	3,600	(492,139)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,358,321)	(12,640,448)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	300,000	2,250,000
C00200	短期借款減少	(300,000)	(2,939,435)
C01600	舉借長期借款	1,919,000	12,277,800
C01700	償還長期借款	(5,539,868)	(5,676,344)
C03000	存入保證金增加	1,241,570	210,311
C03100	存入保證金減少	(114,302)	(72,983)
C04020	租賃負債本金償還	(264,680)	(98,666)
C04500	發放現金股利	(600,000)	(95,234)
C04600	現金增資	-	4,040,000
C05600	支付之利息	(592,042)	(407,151)
C09900	其他預付款項	(79,110)	-
C09900	共同控制下前手權益減少數	-	(1,920,633)
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	(4,029,432)	7,567,665
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(87)	(297)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加（減少）數	2,250,339	(3,008,279)
E00100	年初現金及約當現金餘額	4,171,645	7,179,924
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 6,421,984	$ 4,171,645

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併財務報表附註

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（除另註明外，金額以新台幣仟元為單位）

一、公司沿革

力晶積成電子製造股份有限公司（以下稱「力積電公司」），係由力晶科技股份有限公司（以下稱「力晶公司」）分割設立，以 97 年 4 月 1 日為分割基準日，並經科學工業園區管理局核准設立。主要營業項目為從事各式積體電路之研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工及銷售。力積電公司及其子公司以下合稱「本公司」。

力晶公司為重整集團組織架構，進行以下組織重整：

(一) 力積電公司於 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業，並由力積電公司發行新股予力晶公司作為收購之對價；及由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.（以下稱「Global Powertec 公司」）讓與力積電公司；

(二) 108 年 4 月 1 日由力積電公司將持股 100%之富碩投資股份有限公司（以下稱「富碩公司」）及 Sprout International Limited（以下稱「Sprout 公司」）全數出售予力晶公司。

力晶公司於 109 年 6 月辦理減資，將所持有之力積電公司股票抵充應退還之減資股款，致力晶公司對力積電公司持股比例由 87.12%降至 26.82%，對力積電公司具有重大影響力。

本公司股票自 109 年 12 月起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。

本合併財務報告係以力積電公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告於 110 年 3 月 9 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

除下列說明外，適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動：

1. 國際會計準則第 1 號及國際會計準則第 8 號之修正「重大性之定義」

本公司自 109 年 1 月 1 日開始適用該修正，改以「可被合理預期將影響使用者」作為重大性之門檻，並調整合併財務報告之揭露，刪除可能使重大資訊模糊化之不重大資訊。

(二) 110 年適用之金管會認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會（IASB）發布之生效日
國際財務報導準則第 4 號之修正「適用國際財務報導準則第 9 號之暫時豁免之展延」	發布日起生效
國際財務報導準則第 9 號、國際會計準則第 39 號、國際財務報導準則第 7 號、國際財務報導準則第 4 號及國際財務報導準則第 16 號之修正「利率指標變革－第二階段」	2021 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間生效
國際財務報導準則第 16 號之修正「新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓」	2020 年 6 月 1 日以後開始之年度報導期間生效

除上述影響外，截至本合併財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註 1)
「2018-2020 週期之年度改善」	2022 年 1 月 1 日（註 2）
國際財務報導準則第 3 號之修正「更新對觀念架構之索引」	2022 年 1 月 1 日（註 3）
國際財務報導準則第 10 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未　　定

（接次頁）

（承前頁）

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB發布之生效日(註1)
國際財務報導準則第17號「保險合約」	2023年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正	2023年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債分類為流動或非流動」	2023年1月1日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	2023年1月1日（註6）
國際會計準則第8號之修正「會計估計之定義」	2023年1月1日（註7）
國際會計準則第16號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	2022年1月1日（註4）
國際會計準則第37號之修正「虧損性合約－履行合約之成本」	2022年1月1日（註5）

註1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註2：國際財務報導準則第9號之修正適用於2022年1月1日以後開始之年度報導期間所發生之金融負債之交換或條款修改；國際會計準則第41號「農業」之修正適用於2022年1月1日以後開始之年度報導期間之公允價值衡量；國際財務報導準則第1號「首次採用IFRSs」之修正係追溯適用於2022年1月1日以後開始之年度報導期間。

註3：收購日在年度報導期間開始於2022年1月1日以後之企業合併適用此項修正。

註4：於2021年1月1日（最早表達期間開始日）以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備適用此項修正。

註5：於2022年1月1日尚未履行所有義務之合約適用此項修正。

註6：於2023年1月1日以後開始之年度報導期間推延適用此項修正。

註7：於2023年1月1日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計變動及會計政策變動適用此項修正。

截至本合併財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估上述準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IFRSs 編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。歷史成本通常係依取得資產所支付對價之公允價值決定。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債（即使於資產負債表日後至通過發布財務報告前已完成長期性之再融資或重新安排付款協議，亦屬流動負債），以及

3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少12個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 合併基礎

本合併財務報告係包含力積電公司及由力積電公司所控制個體（子公司）之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整，以使其會計政策與本公司之會計政策一致。於編製合併財務報告時，各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至本公司業主及非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當力積電公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。

子公司明細、持股比率及營業項目，參閱附註十及附表三。

(五) 企業合併

企業合併係採收購法處理。收購相關成本於成本發生及勞務取得當期列為費用。

商譽係按移轉對價之公允價值、被收購者之非控制權益金額以及收購者先前已持有被收購者之權益於收購日之公允價值之總額，超過收購日所取得可辨認資產及承擔負債之淨額衡量。

(六) 外　　幣

各個體編製財務報告時，以個體功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。除為規避部分匯率風險而進行避險交易所產生之兌換差額外，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製合併財務報告時，本公司國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額列於其他綜合損益。

若本公司處分國外營運機構之所有權益，或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制，或處分國外營運機構之聯合協議或關聯企業後之保留權益係金融資產並按金融工具之會計政策處理，所有與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制，係按比例將累計兌換差額併入權益交易計算，但不認列為損益。在其他任何部分處分國外營運機構之情況下，累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

(七) 存　　貨

存貨包括原料、在製品及製成品，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。另固定製造費用應按生產設備之正常產能分攤，因產能較低或設備閒置導致之未分攤固定製造費用，應於發生當年度認列銷貨成本。

本公司之存貨平時按標準成本計價，結帳日再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。

(八) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損損失後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(九) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，並且於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視。並推延適用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除　　列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(十) 不動產、廠房及設備、使用權資產、無形資產及合約成本相關資產之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產、無形資產及合約成本相關資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至個別現金產生單位。

針對非確定耐用年限及尚未可供使用之無形資產，至少每年及有減損跡象時進行減損測試。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

適用國際財務報導準則第 15 號之客戶合約，因客戶合約所認列之存貨、不動產、廠房及設備及無形資產先依存貨減損規定及上述規定認列減損，次依合約成本相關資產之帳面金額超過提供相關商品或勞務預期可收取之對價剩餘金額扣除直接相關成本後之金額認列為減損損失，續將合約成本相關資產之帳面金額計入所屬現金產生單位，以進行現金產生單位之減損評估。

當減損損失於後續迴轉時，該資產、現金產生單位或合約成本相關資產之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產、現金產生單位或合約成本相關資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十一) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於合併資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

金融資產係分為透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資及按攤銷後成本衡量之金融資產。

A.透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產係強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。其產生之利益或損失係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

B.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

本公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，其後續公允價值變動認列於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於本公司具收款之權利時認列於損益，除非該收款之權利明顯代表部分投資成本之回收。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

C.按攤銷後成本衡量

現金及約當現金、債務工具投資、應收帳款（含關係人）、其他應收款項、受限制存款及存出保證金係按攤銷後成本衡量。

債務工具投資之合約條款為完全支付本金及流通在外本金金額之利息，且持有目的係以收取合約現金流量，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

按攤銷後成本衡量之各類金融資產於原始認列後，係以有效利息法決定之帳面價值減除任何減損損失之攤銷後成本衡量。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產及合約資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）。

應收帳款按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增

加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

於一按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。於一透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

2. 權益工具

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

3. 金融負債

(1) 後續衡量

除透過損益按公允價值衡量之金融負債外，所有金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量：

<u>透過損益按公允價值衡量之金融負債</u>

透過損益按公允價值衡量之金融負債包含持有供交易之金融負債。

持有供交易之金融負債係按公允價值衡量，其再衡量產生之利益或損失（包含該金融負債所支付之任何股利或

利息）係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

4. 衍生工具

本公司簽訂之衍生工具包括遠期外匯合約，用以管理本公司之匯率風險。

衍生工具於簽訂衍生工具合約時，原始以公允價值認列，後續於資產負債表日按公允價值再衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

(十二) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，並於滿足各履約義務時認列收入。

<u>商品銷貨收入</u>

商品銷貨收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。本公司基於歷史經驗及考量不同之合約條件，以估計可能發生之銷貨退回及折讓，據以認列退款負債。

商品銷貨收入來自矽晶圓產品之銷售。產品於出貨時或運抵客戶指定地點時認列收入及應收帳款。銷售之預收款項，於商品認列收入前係認列為合約負債。

(十三) 租　　賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 本公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

本公司於轉租使用權資產時，係以使用權資產（而非標的資產）判斷轉租之分類。惟若主租賃係本公司適用認列豁免之短期租賃時，該轉租分類為營業租賃。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。因取得營業租賃所發生之原始直接成本，係加計至標的資產之帳面金額，並按直線基礎於租賃期間內認列為費用，與承租人進行之租賃協商係於租賃修改生效日起按新租賃處理。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為收益。

2. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於合併資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。若租賃期間屆滿時將取得標的資產所有權，或若使用權資產之成本反映購買選擇權之行使，則自租賃開始日起至標的資產耐用年限屆滿時提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。對於不以單獨租賃處理之租賃修改，因減少租賃範圍之租賃負債再衡量係調減使用權資產，並認列租賃部分或全面終止之損益；因其他修改之租賃負債再衡量係調整使用權資產。租賃負債係單獨表達於合併資產負債表。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為費用。

(十四) 借款成本

直接可歸屬於取得及建造符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，所有其他借款成本係於發生當期認列為損益。

(十五) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務之期間，將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服

務成本及前期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時、計畫修正或縮減時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益、資產上限影響數之變動及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債係確定福利退休計畫之提撥短絀。

(十六) 股份基礎給付協議

給與員工之員工認股權

員工認股權係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。本公司辦理現金增資保留員工認購，係確認員工認購股數之日為給與日。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積。

(十七) 所得稅

所得稅費用係當期應付所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

合併公司依各所得稅申報轄區所制定之法規決定當期所得（損失），據以計算應付（可回收）之所得稅。

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司、關聯企業及合資權益相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資及權益有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能有足夠課稅所得用以實現暫時性差異之利益，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、<u>重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源</u>

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本公司將新型冠狀病毒肺炎疫情造成之經濟影響納入重大會計估計之考量，管理階層將對估計與基本假設持續檢視。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

重大會計判斷

(一) 租賃期間

決定所承租資產之租賃期間時，本公司考量將產生經濟誘因以行使（或不行使）選擇權之所有攸關事實及情況，包括自租賃開始日至選擇權行使日間所有事實及情況之預期變動。考量主要因素包括選擇權所涵蓋期間之合約條款及條件、於合約期間進行之重大租賃權益改良及標的資產對承租人營運之重要性等。於本公司控制範圍內重大事項或情況重大改變發生時，重評估租賃期間。

估計及假設不確定性之主要來源

(一) 所得稅

遞延所得稅資產係於未來很有可能有足夠之課稅所得供可減除暫時性差異使用時方予以認列。評估遞延所得稅資產之可實現性時，必須涉及管理階層之重大會計判斷及估計，包含預期未來銷貨收入成長及利潤率、可使用之所得稅抵減及稅務規畫等假設。任何關於全球經濟環境、產業環境的變遷及法令的改變，均可能引起遞延所得稅資產之重大調整。

(二) 承租人增額借款利率

決定租賃給付折現所使用之承租人增額借款利率，係以相當存續期間及幣別之無風險利率做為參考利率，並將所估計之承租人信用風險貼水及租賃特定調整（例如，資產特性及附有擔保等因素）納入考量。

六、現金及約當現金

	109年12月31日	108年12月31日
活期存款	$ 3,649,874	$ 2,044,064
支票存款	19,044	15,780
庫存現金	54	106
約當現金		
銀行定期存款	4,645,943	3,708,226
附買回債券	-	300,000
	8,314,915	6,068,176
受限制存款（帳列其他金融資產）	(1,892,931)	(1,896,531)
合　　計	$ 6,421,984	$ 4,171,645

銀行存款及附買回債券於資產負債表日之市場利率區間如下：

	109年12月31日	108年12月31日
銀行存款	0%~2.40%	0%~2.60%
附買回債券	-	0.53%

七、透過損益按公允價值衡量之金融資產

	109年12月31日	108年12月31日
金融資產－流動		
強制透過損益按公允價值衡量		
衍生工具		
－遠期外匯合約	$ 6,798	$ 4,372

於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下：

	幣別	到期期間	合約金額（仟元）
109 年 12 月 31 日			
賣出遠期外匯	美金兌日圓	110.01.07~110.02.08	USD 22,553/ JPY 2,350,000
108 年 12 月 31 日			
賣出遠期外匯	美金兌新台幣	109.01.03	USD 5,000/ NTD 152,300
	美金兌日圓	109.01.06~109.01.30	USD 13,736/ JPY 1,500,000

本公司從事遠期外匯交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。

八、應收帳款

	109年12月31日	108年12月31日
按攤銷後成本衡量		
應收帳款－非關係人	$ 5,981,210	$ 5,344,970
減：備抵損失	-	-
	5,981,210	5,344,970
應收帳款－關係人	253,494	49,914
減：備抵損失	-	-
	253,494	49,914
應收帳款淨額	$ 6,234,704	$ 5,394,884

本公司對商品銷售之平均授信期間為月結 30～60 天，應收帳款不予計息。為減輕信用風險，本公司管理階層依公司相關之政策、程序及內部控制，指派專責團隊負責授信作業及其他監控程序，以確保逾

期應收帳款之回收已採取適當行動，並按權責由管理階層負責授信額度之決定及授信核准。此外，本公司會定期逐一複核應收帳款之可回收金額以確保無法回收之應收帳款項已提列適當減損損失。

本公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量 GDP 預測及產業展望。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期，本公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

109 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期超過 90 天	合計
總帳面金額	$6,101,702	$ 125,424	$ 7,578	$ -	$ -	$6,234,704
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$6,101,702	$ 125,424	$ 7,578	$ -	$ -	$6,234,704

108 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期超過 90 天	合計
總帳面金額	$4,620,136	$ 768,649	$ 6,099	$ -	$ -	$5,394,884
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$4,620,136	$ 768,649	$ 6,099	$ -	$ -	$5,394,884

九、存　　貨

	109年12月31日	108年12月31日
製成品	$ 598,004	$ 542,260
在製品	4,443,891	3,842,467
原　料	2,776,716	2,000,770
	$ 7,818,611	$ 6,385,497

109 及 108 年度與存貨相關之銷貨成本分別為 34,692,204 仟元及 32,896,453 仟元。

109 及 108 年度之銷貨成本包括實際產能使用較低所導致之未分攤固定製造費用分別為 252,287 仟元及 3,064,643 仟元，109 年認列存

貨呆滯及跌價回升利益 481,318 仟元，主係因產品價格回升所致；108 年提列存貨呆滯及跌價損失 350,932 仟元。

十、子公司

列入合併財務報告之子公司

本合併財務報告編製主體如下：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比 109年12月31日	所持股權百分比 108年12月31日	說明
力積電公司	Global Powertec Co., Ltd.（Global Powertec 公司）	各項投資業務	100%	100%	註一
Global Powertec 公司	PowerMemory Inc.（PowerMemory 公司）	半導體及各式電子產品開發、製造、銷售及輸出入	100%	100%	
	Maxram Inc.（Maxram 公司）	半導體及各式電子產品開發、製造、銷售及輸出入	100%	100%	註二

註一：本公司為重整集團組織架構，於 108 年 4 月 1 日由力積電公司將持股 100%之富碩公司及 Sprout 公司全數出售予力晶公司；於 108 年 5 月 1 日由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec 公司依企業併購法讓與力積電公司。

註二：Global Powertec 公司於 108 年 3 月 22 日取得該公司 100%之股權。

十一、不動產、廠房及設備

自　　用

	109年12月31日	108年12月31日
自　　用	$ 47,218,447	$ 47,362,848

	109年12月31日	108年12月31日
房屋及建築	$ 4,189,877	$ 4,380,121
機器設備	33,930,415	31,651,873
研發設備	1,685,369	1,837,813
廠務設備	6,415,656	6,207,126
運輸設備	2,156	2,719
生財器具	89,839	82,070
租賃改良	3,622	2,859
其他設備	85,574	120,452
待驗設備及未完工程	815,939	3,077,815
	$ 47,218,447	$ 47,362,848

	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
	年初餘額	增加	出售或報廢	淨兌換差額	科目移轉	年底餘額
成本						
房屋及建築	$ 11,660,693	$ -	$ -	$ -	$ 30,411	$ 11,691,104
機器設備	207,574,333	-	(2,132,385)	-	6,513,819	211,955,767
研發設備	3,017,271	-	(23,644)	-	188,265	3,181,892
廠務設備	31,064,913	-	-	-	729,036	31,793,949
運輸設備	11,699	-	-	-	-	11,699
生財器具	634,368	227	(16,438)	(15)	52,029	670,171
租賃改良	3,598	1,035	-	(22)	-	4,611
其他設備	1,854,885	-	(1,530)	-	42,610	1,895,965
	255,821,760	$ 1,262	($ 2,173,997)	($ 37)	$ 7,556,170	261,205,158
累計折舊						
房屋及建築	7,280,572	$ 220,655	$ -	$ -	$ -	7,501,227
機器設備	175,883,873	4,350,659	(2,067,901)	-	(179,412)	177,987,219
研發設備	1,179,458	155,836	(23,644)	-	184,873	1,496,523
廠務設備	24,857,787	526,724	-	-	(6,218)	25,378,293
運輸設備	8,980	563	-	-	-	9,543
生財器具	552,298	44,470	(16,438)	(7)	9	580,332
租賃改良	739	255	-	(5)	-	989
其他設備	1,734,433	76,740	(1,530)	-	748	1,810,391
	211,498,140	$ 5,375,902	($ 2,109,513)	($ 12)	$ -	214,764,517
累計減損						
機器設備	38,587	$ -	($ 454)	$ -	$ -	38,133
待驗設備及未完工程	3,077,815	$ 5,294,294	$ -	$ -	($ 7,556,170)	815,939
淨額	$ 47,362,848					$ 47,218,447

	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日					
	年初餘額	增加	出售或報廢	淨兌換差額	科目移轉	年底餘額
成本						
房屋及建築	$ 11,527,161	$ -	$ -	$ -	$ 133,532	$ 11,660,693
機器設備	201,763,144	-	(4,145,292)	-	9,956,481	207,574,333
研發設備	2,064,558	-	(5,918)	-	958,631	3,017,271
廠務設備	29,605,077	-	(5,138)	-	1,464,974	31,064,913
運輸設備	10,239	-	-	-	1,460	11,699
生財器具	604,613	974	(8,336)	(13)	37,130	634,368
租賃改良	1,216	2,398	-	(16)	-	3,598
其他設備	1,783,576	-	(4,626)	-	75,935	1,854,885
	247,359,584	$ 3,372	($ 4,169,310)	($ 29)	$ 12,628,143	255,821,760
累計折舊						
房屋及建築	7,062,740	$ 217,832	$ -	$ -	$ -	7,280,572
機器設備	176,361,044	3,804,839	(4,088,777)	-	(193,233)	175,883,873
研發設備	866,937	126,983	(5,918)	-	191,456	1,179,458
廠務設備	24,451,844	411,078	(5,135)	-	-	24,857,787
運輸設備	8,640	340	-	-	-	8,980
生財器具	523,320	37,318	(8,336)	(4)	-	552,298
租賃改良	638	105	-	(4)	-	739
其他設備	1,655,834	81,798	(4,626)	-	1,427	1,734,433
	210,930,997	$ 4,680,293	($ 4,112,792)	($ 8)	($ 350)	211,498,140
累計減損						
機器設備	38,587	$ -	$ -	$ -	$ -	38,587
待驗設備及未完工程	4,298,694	$ 11,407,264	$ -	$ -	($ 12,628,143)	3,077,815
淨額	$ 40,688,694					$ 47,362,848

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

房屋及建築	21 至 40 年
機器設備	1.5 至 19 年
研發設備	1.5 至 19 年
廠務設備	6 至 30 年
運輸設備	6 年
生財器具	2 至 7 年
租賃改良	4 至 16 年
其他設備	4 年

本公司設定質押作為借款擔保之不動產、廠房及設備金額，請參閱附註十四及二八。

十二、租賃協議

(一) 使用權資產

	109年12月31日	108年12月31日
使用權資產帳面金額		
土　　地	$ 2,087,674	$ 1,523,791
建 築 物	138,400	149,983
機器設備	4,941,786	2,696,447
運輸設備	14,910	23,724
	$ 7,182,770	$ 4,393,945

	109年度	108年度
使用權資產之增添	$ 3,277,223	$ 2,768,430
使用權資產之折舊費用		
土　　地	$ 78,538	$ 70,872
建 築 物	31,975	32,236
機器設備	354,023	55,120
運輸設備	11,971	9,656
	$ 476,507	$ 167,884

(二) 租賃負債

	109年12月31日	108年12月31日
租賃負債帳面金額		
流　　動	$ 354,050	$ 215,566
非 流 動	$ 6,659,024	$ 4,083,303

租賃負債之折現率區間如下：

	109年12月31日	108年12月31日
土　　地	2.92%~3.74%	2.92%
建 築 物	1.79%~2.64%	1.79%~2.64%
機器設備	1.61%~4.58%	1.83%~4.58%
運輸設備	1.77%~1.97%	1.79%~1.97%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租若干土地及建築物做為廠房及辦公室使用，主要租賃期間為 20 年。位於中華民國之土地租賃約定每 2 年依公告地價調

整租賃給付。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之土地及建築物並無優惠承購權。

本公司承租若干機器設備以供營業使用，租賃期間為 10 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之機器設備並無優惠承購權。

本公司另以融資租賃方式承租若干機器設備，租賃期間為 4.5 年～6.2 年。於租賃期間屆滿時，該機器設備所有權自動移轉為本公司所有。本公司之融資租賃義務係以出租人保有租賃資產之所有權作為擔保。

本公司承租若干公務車以供營業使用，租賃期間為 3～4 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之公務車並無優惠承購權。

(四) 其他租賃資訊

	109年度	108年度
短期租賃費用	$ 14,401	$ 16,672
租賃之現金流出總額(含使用權資產)	$416,986	$158,640

本公司選擇對符合短期租賃之場地、機器設備與公務車租賃適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

十三、無形資產

	109年12月31日	108年12月31日
技術移轉及授權費	$110,606	$ 55,876
專 利 權	117,507	136,454
電腦軟體設備及系統費	18,841	45,180
其　　他	9,787	4,310
	$256,741	$241,820

	技術移轉及授權費	電腦軟體設備及系統費	專利權	其他	合計
成　本					
109年1月1日餘額	$1,324,100	$ 68,488	$ 307,550	$ 8,967	$1,709,105
增　添	118,507	3,638	12,000	7,443	141,588
本期攤提完畢	(1,324,100)	(19,266)	-	(1,294)	(1,344,660)
淨兌換差額	-	(1)	-	-	(1)
109年12月31日餘額	$ 118,507	$ 52,859	$ 319,550	$ 15,116	$ 506,032

(接次頁)

（承前頁）

	技術移轉及授權費	電腦軟體設備及系統費	專利權	其他	合計
累計攤銷					
109年1月1日餘額	$1,268,224	$ 23,308	$ 171,096	$ 4,657	$1,467,285
攤銷費用	63,777	29,977	30,947	1,966	126,667
本期攤提完畢	(1,324,100)	(19,266)	-	(1,294)	(1,344,660)
淨兌換差額	-	(1)	-	-	(1)
109年12月31日餘額	$ 7,901	$ 34,018	$ 202,043	$ 5,329	$ 249,291
108年12月31日及109年1月1日淨額	$ 55,876	$ 45,180	$ 136,454	$ 4,310	$ 241,820
109年12月31日淨額	$ 110,606	$ 18,841	$ 117,507	$ 9,787	$ 256,741
成本					
108年1月1日餘額	$1,324,100	$ 181,484	$ 307,550	$ 27,699	$1,840,833
增添	-	46,594	-	-	46,594
本期攤提完畢	-	(159,589)	-	(18,732)	(178,321)
淨兌換差額	-	(1)	-	-	(1)
108年12月31日餘額	$1,324,100	$ 68,488	$ 307,550	$ 8,967	$1,709,105
累計攤銷					
108年1月1日餘額	$1,003,404	$ 151,502	$ 140,750	$ 18,115	$1,313,771
攤銷費用	264,820	31,396	30,346	5,274	331,836
本期攤提完畢	-	(159,589)	-	(18,732)	(178,321)
淨兌換差額	-	(1)	-	-	(1)
108年12月31日餘額	$1,268,224	$ 23,308	$ 171,096	$ 4,657	$1,467,285
108年12月31日淨額	$ 55,876	$ 45,180	$ 136,454	$ 4,310	$ 241,820

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

技術移轉及授權費	5年
電腦軟體設備及系統費	2至4年
專利權	5至15年
其他	2至5年

十四、借款

長期借款

	109年12月31日	108年12月31日
擔保借款		
一長期抵押聯合貸款(一)	$15,058,180	$20,064,077
一長期抵押聯合貸款(二)	4,199,384	3,941,600
一長期抵押聯合貸款(三)	2,779,137	1,279,285

（接次頁）

（承前頁）

	109年12月31日	108年12月31日
－關係人借款（參閱附註二七）	$ 735,000	$ -
－其　　他	865,300	865,300
小　　計	23,637,001	26,150,262
無擔保借款		
－銀行借款	175,000	525,000
	23,812,001	26,675,262
減：列為1年內到期部分	(7,065,983)	(5,512,049)
長期借款	$16,746,018	$21,163,213

力晶公司於 107 年 3 月 14 日簽署長期抵押聯合貸款(一)之授信合約、分別於 107 年 12 月 10 日、108 年 12 月 25 日及 109 年 5 月 29 日簽署第一次、第二次及第三次增補合約，授信額度變更為新臺幣 24,500,000 仟元。依聯貸合約約定按季還本，到期日為 112 年 12 月，109 年及 108 年 12 月 31 日有效利率為 1.79%。主要承諾事項如下：

(一) 力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，將聯合授信合約下之權利義務，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，本授信案由力積電公司擔任借款人。

(二) 力積電公司需於額度管理銀行開立營運收支專戶該專戶之餘額應於每季末檢視當季累積存（匯）入金額不得低於新台幣 6,000,000 仟元或等值外幣。

(三) 力積電公司於本授信案期間，每年資本支出加計非資本支出及現金股利之支出限額，不得超逾前一年度之稅後淨利加計折舊並扣除特別保留份額。非資本支出，係指包括借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款及與借款人本業相關之長、短期投資股票或股權支出。但借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款屬借新還舊者不在此限。前述支出限額，依第二次增補合約規定，109 年為一固定限額，自 110 年起則不得超逾前一期期末之稅後淨利減除重大無現金流量之收入，加計折舊並扣除特別保留份額。

(四) 力積電公司於本授信案期間，每季需提供經額度管理銀行同意之會計師就資本支出、支出限額及相關約定之查核或檢核報告予額度管理銀行。

(五) 於債務清償前，力積電公司之年度合併財務報表受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之限制。本公司截至 109 年 12 月 31 日止之各項財務比率均符合合約規定。

長期抵押聯合貸款(二)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 114 年 1 月，截至 109 年及 108 年 12 月 31 日有效利率分別為 1.87%及 1.86%。另貸款合約規定，力積電公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之限制。力積電公司截至 109 年 12 月 31 日止之各項財務比率均符合合約規定。

長期抵押聯合貸款(三)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 113 年 2 月，截至 109 年及 108 年 12 月 31 日有效利率分別為 1.87%及 1.86%。另貸款合約規定，力積電公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有負債比率、流動比率及利息保障倍數等限制。力積電公司截至 109 年 12 月 31 日止之各項財務比率均符合合約規定。

為償還既有金融機構借款，並充實中長期營運資金及購置機器設備暨其附屬設備，力積電公司於 109 年 11 月與金融機構簽訂新台幣 29,300,000 仟元之聯合授信合約。截至 109 年 12 月 31 日止，前述授信額度尚未動用，惟上述授信合約已於 110 年 1 月 18 日動撥 15,059,605 仟元。

長期借款擔保之情形，請參閱附註二八。

力晶公司分別於 106 年 9 月及 106 年 12 月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約約定按季還本，到期日為 109 年 9 月至 109 年 12 月。

力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於 108 年 4 月簽署中長期授信增補合約，將授信合約下之債務、權利及義務，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，前述

無擔保銀行中長期額度貸款由力積電公司擔任借款人。截至 109 年 12 月止，前述中長期借款已清償完畢。

力積電公司分別於 108 年 5 月及 108 年 7 月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約規定每半年還本，到期日分別為 111 年 5 月及 110 年 7 月，截至 109 年 12 月 31 日止，年利率分別為 1.35%及 1.32%。

關係人借款：力積電公司於 109 年 3 月與關係人簽訂設備買賣融資借款，依合約約定按季付息，相關款項於到期日 111 年 4 月付清，截至 109 年 12 月 31 日止，年利率為 1.80%。關係人交易請參閱附註二七。擔保之情形請參閱附註二八。

其他借款：力晶公司於 106 年 5 月至 10 月與金士頓公司承作設備買賣融資借款，相關款項於到期日 108 年 10 月一次支付。依設備買賣融資需支付價款設算隱含利率約為 2.78%至 2.89%。力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，本融資借款由力積電公司擔任借款人。前述借款於 108 年 9 月簽署增補合約，對方約定於 110 年 10 月一次清償借款，截至 109 年 12 月 31 日止，年利率為 1.80%。擔保之情形請參閱附註二八。

十五、其他應付款

	109年12月31日	108年12月31日
應付薪資及獎金	$ 1,365,086	$ 1,231,066
應付員工及董事酬勞	542,871	-
應付權利金	303,512	488,941
應付電費	193,478	188,870
應付利息	131,742	120,733
其　　他	1,674,082	1,718,121
	$ 4,210,771	$ 3,747,731

十六、其他流動負債

	109年12月31日	108年12月31日
存入保證金	$ 415,357	$ 161,647
退款負債	190,000	191,000
其　　他	484,544	727,086
	$ 1,089,901	$ 1,079,733

十七、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

力積電公司適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

(二) 確定福利計畫

力積電公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。該等公司按員工每月薪資總額 2%提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，該等公司並無影響投資管理策略之權利。

列入合併資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	109年12月31日	108年12月31日
已提撥確定福利義務之現值	$ 2,712,605	$ 2,605,324
計畫資產公允價值	(1,190,134)	(1,040,191)
淨確定福利負債	$ 1,522,471	$ 1,565,133

淨確定福利負債變動如下：

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
108 年 1 月 1 日	$ 2,467,078	($ 892,586)	$ 1,574,492
當期服務成本	17,760	-	17,760
利息費用（收入）	14,696	(5,239)	9,457
認列於損益	32,456	(5,239)	27,217
再衡量數			
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	-	(991)	(991)
精算損失－人口統計假設變動	3,943	-	3,943

（接次頁）

（承前頁）

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
精算損失－財務假設變動	$ 115,082	$ -	$ 115,082
精算損失－經驗調整	(7,109)	-	(7,109)
認列於其他綜合損益	111,916	(991)	110,925
雇主提撥	-	(72,834)	(72,834)
福利支付	(21,135)	6,989	(14,146)
認列人口併入影響數	15,009	(75,530)	(60,521)
108 年 12 月 31 日	2,605,324	(1,040,191)	1,565,133
當期服務成本	25,834	-	25,834
利息費用（收入）	19,355	(7,764)	11,591
認列於損益	45,189	(7,764)	37,425
再衡量數			
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	-	(32,597)	(32,597)
精算損失－人口統計假設變動	1,463	-	1,463
精算損失－財務假設變動	105,881	-	105,881
精算損失－經驗調整	12,017	-	12,017
認列於其他綜合損益	119,361	(32,597)	86,764
雇主提撥	-	(125,517)	(125,517)
福利支付	(57,269)	15,935	(41,334)
109 年 12 月 31 日	$ 2,712,605	($ 1,190,134)	$ 1,522,471

力積電公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟力積電公司之計畫資產得分配金額係以不低於當地銀行 2 年定期存款利率。如有低於該利率之情形，由國庫補足。

2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

力積電公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	109年12月31日	108年12月31日
折 現 率	0.40%	0.75%
薪資預期增加率	4.20%	4.25%
離 職 率	0.61%	0.71%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	109年12月31日	108年12月31日
折 現 率		
增加 0.25%	($ 87,916)	($ 87,141)
增加 10%	($ 35,627)	
減少 0.25%	$ 91,850	$ 91,170
減少 10%	$ 36,257	
薪資預期增加率		
增加 0.25%	$ 86,317	$ 85,929
減少 0.25%	($ 83,166)	($ 82,667)
離 職 率		
離職率 110%	($ 849)	($ 1,411)
離職率 90%	$ 851	$ 1,415

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	109年12月31日	108年12月31日
預期 1 年內提撥金額	$ 40,262	$ 39,360
確定福利義務加權平均存續期間	13 年	13 年

十八、權　　益

(一) 普通股股本

	109年12月31日	108年12月31日
額定股數（仟股）	5,000,000	5,000,000
額定股本	$50,000,000	$50,000,000
已發行且已收足股款之股數（仟股）	3,105,196	3,105,196
已發行股本	$31,051,965	$31,051,965

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為 500,000 仟股。

力積電公司股本變動主要係因股票股利、現金增資及組織重組發行新股。

力積電公司於 107 年 9 月 4 日董事會決議，為進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業（含資產、負債及營業），並由力積電公司發行新股予力晶公司作為收購之對價，計發行新股 2,260,818 仟股，並以 108 年 5 月 7 日為收購發行新股基準日，已於 108 年 5 月 13 日辦理變更登記完竣。

力積電公司經董事會決議現金增資發行新股，並於 108 年 6 月 28 日經董事會決議調整最終股數及募集金額，辦理現金增資發行新股 400,000 仟股，每股面額 10 元，以每股新台幣 10.1 元發行，本次以 108 年 9 月 20 日為增資基準日。

上述現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數之 13.5%由員工認購，其餘之 86.5%計 346,000 仟股，依力積電公司原股東力晶公司 108 年度股東常會決議將其認購權利讓與力晶公司全體股東。

力積電公司為配合擴充產能、提升生產製程及增進研發能力所需購置相關設備，於 110 年 3 月 9 日董事會決議，擬現金增資發行新股 300,000 仟股，每股面額 10 元，預計發行後流通在外股數 3,405,196 仟股。

(二) 資本公積

	109年12月31日	108年12月31日
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)		
股票發行溢價	$170,680	$170,680
受贈資產	8	-
僅得用以彌補虧損		
員工認股權執行轉入之金額	11,247	11,247
不得作為任何用途		
發行員工認股權	221,681	-
	$403,616	$181,927

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利

依力積電公司 108 年 3 月 12 日修正後章程之盈餘分派政策規定，力積電公司盈餘分派或虧損彌補得於每半會計年度終了後為之。每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達力積電公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後之。力積電公司章程規定之員工及董事酬勞分派政策，參閱附註二十之(七)員工酬勞及董事酬勞。

力積電公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中現金股利於股利總額之 10%～100%，股票股利於股利總額之 0%～90%。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

力積電公司於 108 年 4 月 12 日董事會（代行股東會職權），決議通過 107 年度盈餘分配案如下：

	盈餘分配表
	107年度
法定盈餘公積	$ 98,593
現金股利	95,234
股票股利	857,109
每股現金股利（元）	0.27
每股股票股利（元）	2.39

力積電公司於 109 年 5 月 27 日股東常會決議通過 108 年度虧損撥補案，以法定盈餘公積彌補虧損 238,155 仟元。

力積電公司於 109 年 7 月 28 日董事會決議 109 年上半年度盈餘分配案如下：

	109年1月1日 至6月30日
法定盈餘公積	$ 66,806
現金股利	$600,000
每股現金股利（元）	$ 0.19

力積電公司於 110 年 3 月 9 日董事會擬議 109 年下半年度盈餘分配案如下：

	109年7月1日 至12月31日
法定盈餘公積	$ 169,443
特別盈餘公積	$ 380
現金股利	$ 1,525,867
每股現金股利（元）	$ 0.49

上述現金股利已由董事會決議分配，並預計於 110 年 6 月 9 日召開之股東常會報告。

(四) 其他權益項目

其他權益項目之變動數如下：

109 年度

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額
年初餘額	($ 294)
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額	(86)
年底餘額	($ 380)

108 年度

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計
年初餘額	($ 4,316)	$ 356	($ 3,960)
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額	(294)	-	(294)
權益工具未實現評價損益	-	39,775	39,775
共同控制下後手由本公司業主權益轉出	4,316	(40,131)	(35,815)
年底餘額	($ 294)	$ -	($ 294)

(五) 庫藏股票

本公司持有之庫藏股票，係 109 年度因受領贈與產生共計 327 股，前述庫藏股票依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派及表決權等權利。

十九、營業收入

	109年度	108年度
客戶合約收入		
商品銷售收入	$45,684,615	$35,897,121

(一) 合約餘額

	109年12月31日	108年12月31日	108年1月1日
應收帳款（附註八）	$ 6,234,704	$ 5,394,884	$ 6,380,859
合約負債			
商品銷售	$ 623,901	$ 808,913	$ 1,138,000
其　　他	77,342	117,446	117,598
	$ 701,243	$ 926,359	$ 1,255,598

來自年初合約負債以及前期已滿足之履約義務於當期認列為收入之金額如下：

	109年度	108年度
來自年初合約負債		
銷貨商品	$552,831	$715,386
其他（帳列其他收益及費損淨額）	92,354	46,922
	$645,185	$762,308

(二) 客戶合約收入之細分

	109年度	108年度
主要地區市場		
台　　灣	$ 32,938,268	$ 23,480,915
中　　國	5,814,356	2,223,105
日　　本	1,700,875	1,487,232
其　　他	5,231,116	8,705,869
	$ 45,684,615	$ 35,897,121
產品項目		
包裝元件	$ 132,019	$ 382,834
晶　　圓	45,552,596	35,514,287
	$ 45,684,615	$ 35,897,121

二十、本年度淨利（損）

(一) 其他收益及費損淨額

	109年度	108年度
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	$ 28,749	$ 950
賠償收入	1,148	141,987
其他收入及支出	182,430	29,748
	$212,327	$172,685

(二) 利息收入

	109年度	108年度
銀行存款	$ 26,684	$ 59,396
附買回債券	1,243	3,093
押金設算息	50	54
	$ 27,977	$ 62,543

(三) 其他利益及損失

	109年度	108年度
外幣兌換淨益損失	($316,469)	($ 68,070)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益	21,504	12,784
	($294,965)	($ 55,286)

(四) 財務成本

	109年度	108年度
借款之利息	$479,135	$437,244
租賃負債之利息	189,059	75,849
其　　他	9,989	10,270
	$678,183	$523,363

利息資本化相關資訊如下：

	109年度	108年度
利息資本化金額	$ 37,406	$ 72,899
利息資本化利率	1.98%~2.24%	1.84%~1.98%

(五) 折舊及攤銷

	109年度	108年度
不動產、廠房及設備	$ 5,375,902	$ 4,680,293
使用權資產	476,507	167,884
無形資產	126,667	331,836
合　　計	$ 5,979,076	$ 5,180,013
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	$ 5,463,750	$ 4,521,636
營業費用	388,659	326,254
其他收益及費用	-	287
	$ 5,852,409	$ 4,848,177

(接次頁)

（承前頁）

	109年度	108年度
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	$ 109,415	$ 318,401
營業費用	17,252	13,435
	$ 126,667	$ 331,836

(六) 員工福利費用

	109年度	108年度
退職後福利		
確定提撥計畫	$ 328,588	$ 320,001
確定福利計畫（附註十七）	37,425	27,217
	366,013	347,218
股份基礎給付		
權益交割	221,681	11,247
其他員工福利	8,915,176	7,709,766
員工福利費用合計	$ 9,502,870	$ 8,068,231
依功能別彙總		
營業成本	$ 6,390,613	$ 5,298,929
營業費用	3,112,257	2,769,302
	$ 9,502,870	$ 8,068,231

(七) 員工酬勞及董事酬勞

力積電公司係以當年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之力積電公司稅前淨利，應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

109 年度員工酬勞及董事酬勞於 110 年 3 月 9 日經董事會決議如下：

金　　額

	109年度	
	現　　金	股　　票
員工酬勞	$482,131	$ -
董事酬勞	60,000	-

108 年度係為稅前淨損，故不估列員工酬勞及董監事酬勞。

年度合併財務報表通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

107 年度員工酬勞及董監事酬勞之實際配發金額與 107 年度合併財務報告之認列金額並無差異。

二一、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅費用主要組成項目

	109年度	108年度
當期所得稅		
本年度產生者	$ 5,275	$ 9,020
以前年度之調整	4,864	(1,321)
	10,139	7,699
遞延所得稅		
本年度產生者	1,508,155	536,517
與所得稅抵減有關	(525,698)	(515,917)
	982,457	20,600
認列於損益之所得稅費用	$ 992,596	$ 28,299

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	109年度	108年度
本年度稅前淨利（損）	$ 4,799,073	($ 2,614,885)
稅前淨利（損）按法定稅率計算之稅額	$ 958,760	($ 528,445)
調節項目之所得稅影響數		
決定課稅所得時不可計入之損益	23,697	15,729
遞延所得稅資產／負債之所得稅影響數	-	533,316
本年度產生者	5,275	9,020
以前年度之調整	4,864	(1,321)
認列於損益之所得稅費用	$ 992,596	$ 28,299

(二) 本期所得稅資產與負債

	109年12月31日	108年12月31日
本期所得稅資產		
應收退稅款	$ 27,721	$ 11,878
本期所得稅負債		
應付所得稅	$ 300	$ 108

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

109 年度

	年初餘額	認列於損益	年底餘額
遞延所得稅資產			
虧損扣抵	$ -	$ 525,698	$ 525,698
暫時性差異			
折舊	129,423	43,473	172,896
備抵存貨跌價損失	249,179	(96,264)	152,915
其他	241,984	(67,122)	174,862
	$ 620,586	$ 405,785	$ 1,026,371
遞延所得稅負債			
暫時性差異			
不動產、廠房及設備	$ 607,796	$ 1,328,063	$ 1,935,859
其他	12,790	60,179	72,969
	$ 620,586	$ 1,388,242	$ 2,008,828

108 年度

	年初餘額	共同控制下前手權益轉出數	認列於損益	年底餘額
遞延所得稅資產				
虧損扣抵	$ 588,356	($ 588,356)	$ -	$ -
暫時性差異				
折舊	56,831	-	72,592	129,423
備抵存貨跌價損失	178,992	(176,029)	246,216	249,179
其他	956,531	(912,217)	197,670	241,984
	$ 1,780,710	($ 1,676,602)	$ 516,478	$ 620,586
遞延所得稅負債				
暫時性差異				
不動產、廠房及設備	$ 1,752,678	($ 1,671,567)	$ 526,685	$ 607,796
其他	7,432	(5,035)	10,393	12,790
	$ 1,760,110	($ 1,676,602)	$ 537,078	$ 620,586

(四) 未於合併資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異、未使用虧損扣抵金額及投資抵減稅額

	109年12月31日	108年12月31日
可減除暫時性差異	$ -	$ 405,547
虧損扣抵	$ 2,803,324	$ 2,406,520
投資抵減	$ 85,079	$ -

(五) 未使用之虧損扣抵及投資抵減相關資訊

截至 109 年 12 月 31 日止，虧損扣抵相關資訊如下：

尚未扣抵餘額	最後扣抵年度
$ 2,406,520	118 年度
3,025,291	119 年度
$ 5,431,811	

截至 109 年 12 月 31 日止，投資抵減相關資訊如下：

法令依據	抵減項目	尚未抵減稅額	最後抵減年度
產業創新條例	研究發展支出	$ 55,079	110 年
產業創新條例	智慧機械投資	30,000	110 年
		$ 85,079	

(六) 所得稅核定情形

力積電公司截至 107 年度以前之營利事業所得稅申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二二、每股盈餘（虧損）

單位：每股元

	109年度	108年度
基本每股盈餘（虧損）	$ 1.23	($ 0.94)
稀釋每股盈餘（虧損）	$ 1.21	($ 0.94)

用以計算每股盈餘（虧損）及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利（損）

	109年度	108年度
歸屬於本公司業主之淨利（損）	$ 3,806,477	($ 1,480,370)
歸屬於共同控制下前手權益淨損	-	(1,162,814)
用以計算基本及稀釋每股盈餘（虧損）之淨利（損）	$ 3,806,477	($ 2,643,184)

股　　數　　單位：仟股

	109年度	108年度
用以計算基本每股盈餘（虧損）之普通股加權平均股數	3,105,197	2,821,863
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工酬勞	45,059	-
用以計算稀釋每股盈餘（虧損）之普通股加權平均股數	3,150,256	2,821,863

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

本公司 108 年度因係虧損，若計入員工酬勞之影響將產生反稀釋作用，是以未納入稀釋每股虧損之計算。

本公司將員工認股權憑證之潛在普通股列入計算 109 年度之稀釋每股盈餘時，因具反稀釋作用，故未納入稀釋每股盈餘之股數計算。

二三、股份基礎給付協議

(一) 現金增資保留員工認股

力積電公司經董事會決議現金增資發行新股，並於 108 年 6 月 28 日經董事會決議調整最終發行股數及募集金額，並依據公司法保留新股總數 13.5%計 54,000 仟股由員工認購。員工認購不足一股之畸零股或放棄認股之股份，則授權董事長洽特定人認購之。

力積電公司於 108 年 7 月 16 日給與之員工認股權，其公平價值使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之參數如下：

衡量日每股股權公平價值	$ 9.89
行使價格	10.10
預期波動率	30.58%
預期存續期間	0.062 年
預期股利率	-
無風險利率	0.48%
認股權公平價值	0.2083

力積電公司 108 年度因現金增資保留員工認購權利認列之酬勞成本為 11,247 仟元。

(二) 員工認股權計畫

力積電公司分別於 109 年 1 月 6 日及 109 年 11 月 10 日經金融監督管理委員會核准發行員工認股權 150,000 仟單位及 300,000 仟單位，每一單位可認購普通股 1 股。認股權之存續期間均為 6 年，憑證持有人於發行屆滿 2 年之日起，可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後，遇有力積電公司普通股股份發生變動時，認股權行使價格依規定公式予以調整。

員工認股權之相關資訊如下：

	109年認股權計畫		108年認股權計畫	
109 年度	單位（仟）	加權平均執行價格（元）	單位（仟）	加權平均執行價格（元）
期初流通在外	-	$ -	-	$ -
本期給與	268,969	15.50	150,000	10.42
本期放棄	(466)	15.50	(4,417)	10.00
期末流通在外	268,503		145,583	
期末可執行	-		-	
本期給與之認股權加權平均公允價值（元）	$ 4.78		$ 3.46	

截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：

	109年12月31日	
認股權計畫	執行價格之範圍（元）	加權平均剩餘合約期限（年）
109 年股權計劃	$ 15.50	5.88
108 年股權計劃	10.00~15.50	5.13

力積電公司於 109 年 1 月 20 日董事會通過 108 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	9.28 元
執行價格	10.00 元
預期波動率	42.70%
存續期間	4.87 年
預期股利率	-
無風險利率	0.53%
認股權公平價值	3.25~3.50

力積電公司於 109 年 11 月 13 日董事會通過 108 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	15.31 元
執行價格	15.50 元
預期波動率	42.58%
存續期間	4.88 年
預期股利率	-
無風險利率	0.22%
認股權公平價值	4.72~4.85

力積電公司於 109 年 11 月 13 日董事會通過 109 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	15.31 元
執行價格	15.50 元
預期波動率	42.58%
存續期間	4.88 年
預期股利率	-
無風險利率	0.22%
認股權公平價值	4.72~4.85

109 年度認列之酬勞成本為 221,681 仟元。

二四、現金流量資訊

(一) 非現金交易

	109年度	108年度
不動產、廠房及設備增加數	$ 5,295,556	$ 11,410,636
應付設備款變動數	222,939	408,910
預付設備款變動數	(1,450,212)	295,175
其　　他	(761,975)	54,686
取得不動產、廠房及設備支付現金數	$ 3,306,308	$ 12,169,407

(二) 來自籌資活動之負債變動

109 年度

	109年1月1日	現金流量	非現金之變動 匯率變動	非現金之變動 其他（註）	109年12月31日
長期借款（含一年內到期之長期借款）	$ 26,675,262	($ 3,620,868)	$ -	$ 757,607	$ 23,812,001
存入保證金	490,868	1,127,268	(49,754)	89,436	1,657,818
租賃負債	4,298,869	(264,680)	(216,797)	3,195,682	7,013,074
長期預付款（帳列其他非流動資產－其他）	6,748	79,110	-	(6,699)	79,159
	$ 31,471,747	($ 2,679,170)	($ 266,551)	$ 4,036,026	$ 32,562,052

108 年度

	108年1月1日	現金流量	非現金之變動 匯率變動	非現金之變動 其他（註）	108年12月31日
短期借款	$ 689,435	($ 689,435)	$ -	$ -	$ -
長期借款（含一年內到期之長期借款）	20,015,725	6,601,456	-	58,081	26,675,262
存入保證金	311,120	137,328	(12,903)	55,323	490,868
租賃負債	-	(98,666)	(73,514)	4,471,049	4,298,869
長期預付款（帳列其他非流動資產－其他）	39,458	-	-	(32,710)	6,748
	$ 21,055,738	$ 5,950,683	($ 86,417)	$ 4,551,743	$ 31,471,747

註：其他包含包含來自客戶合約負債轉入、新增租賃負債及租賃負債財務成本。

二五、資本風險管理

本公司進行資本管理係確保公司能夠於繼續經營之前提下，藉由調整債務與權益最適化，以達成股東權益極大化。

本公司資本結構係由本公司之淨債務（即借款減除現金及約當現金）及歸屬於母公司業主之權益（即股本、資本公積、保留盈餘及其他權益項目）組成。

二六、金融工具

(一) 公允價值之資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

109 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 6,798	$ -	$ 6,798

108 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 4,372	$ -	$ 4,372

109及108年度無第1等級與第2等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 第2等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具－遠期外匯合約	現金流量折現法：按期末之可觀察遠期匯率及合約所訂匯率估計未來現金流量，並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

(三) 金融工具之種類

	109年12月31日	108年12月31日
金融資產		
強制透過損益按公允價值衡量	$ 6,798	$ 4,372
按攤銷後成本衡量之金融資產（註1）	14,798,403	11,925,267
金融負債		
按攤銷後成本衡量（註2）	40,909,490	39,593,407

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款－非關係人淨額、應收帳款－關係人淨額、其他應收款、其他金融資產及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含應付帳款－非關係人、應付設備款、其他應付款、一年內到期之長期借款、租賃負債、長期借款及存入保證金等以攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

本公司之財務風險管理目標，係為管理與營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本公司致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司對於前述財務風險管理已依相關規範建立適當之政策、程序及內部控制，重要財務活動須經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。公司恪遵相關財務操作程序。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）及利率變動風險（參閱下述(2)）。本公司從事衍生金融工具（包括遠期外匯）以管理所承擔之外幣匯率。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而產生匯率變動風險。本公司匯率風險之管理採部分自然避險，並於政策許可之範圍內，利用遠期外匯合約管理風險。本公司之匯率風險管理，以避險為目的，不以獲利為目的。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目），參閱附註三十。

敏感度分析

本公司主要受到美金、日幣、歐元及人民幣匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少 1%時，本公司之敏感度分析。敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其期末之換算以匯率變動 1%予以調整。敏感度分析之範圍包括現金及約當現金、應收帳款（含關係人）、其他應收款、應付帳款、應付設備款、租賃負債及其他應付款。下表之正數係表示當新台幣相對於各相關貨幣貶值 1%時，將使稅前淨利增加之金額；當新台幣相對於各相關貨幣升值 1%時，其對稅前淨利之影響將為同金額之負數。

	美金之影響		日幣之影響		歐元之影響		人民幣之影響	
	109年度	108年度	109年度	108年度	109年度	108年度	109年度	108年度
損益	$ 25,775	$ 19,917	($ 4,417)	($ 2,249)	($ 3,955)	($ 2,863)	$ 133	$ 130

(2) 利率風險

因本公司內個體同時以固定及浮動利率借入資金，因而產生利率暴險。本公司定期評估避險活動，以確保採用最符合成本效益之避險策略。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	109年12月31日	108年12月31日
具公允價值利率風險		
一金融資產	$ 4,645,943	$ 4,008,226
一金融負債	(8,613,374)	(5,164,169)
具現金流量利率風險		
一金融資產	3,649,874	2,044,064
一金融負債	(22,211,701)	(25,809,962)

敏感度分析

有關利率風險之敏感性分析，主要針對資產負債表日浮動利率金融負債之現金流量變動為計算基礎。

若利率增加／減少 0.1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 109 及 108 年度之稅前淨利將分別減少／增加 18,562 仟元及 23,766 仟元，主因為本公司之浮動利率淨負債利率暴險。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成集團財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務及本公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於資產負債表所認列之金融資產帳面金額。

為減輕信用風險，本公司已訂定授信及應收帳款管理辦法，以確保應收帳款之收回，以及逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司會每季逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。

本公司應收帳款之對象涵蓋眾多客戶，分散於不同產業及地理區域。本公司持續地針對應收帳款客戶之財務狀況每年或不定期進行評估。

個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、信評機構評等、本公司內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。本公司定期或不定期針對應收帳款客戶之財務狀況進行評估，必要時亦會要求客戶提供預收貨款、產能保證金、質押定存或其他擔保品，以降低特定客戶的信用風險。

另因流動資金及衍生金融工具之交易對方係信用良好之銀行，故該信用風險係屬有限。

3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應集團營運並減輕現金流量波動之影響。

銀行借款對本公司而言係為一項主要流動性風險來源。截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，本公司未動用之融資額度參閱下列(3)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依本公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。因此，本公司可被要求立即還款之銀行借款，係列於下表最早之期間內，不考慮銀行立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

109 年 12 月 31 日

	1 年 以 下	1 ～ 5 年	5 年 以 上	合 計
非衍生金融負債				
無附息負債	$ 8,426,597	$ -	$ -	$ 8,426,597
租賃負債	494,973	4,412,787	3,817,566	8,725,326
浮動利率工具	6,223,468	16,034,137	-	22,257,605
固定利率工具	894,062	741,597	-	1,635,659
	$16,039,100	$21,188,521	$ 3,817,566	$41,045,187

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1年以內	1～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上
租賃負債	$ 494,973	$ 4,412,787	$ 1,870,684	$ 638,721	$ 572,376	$ 735,785

108 年 12 月 31 日

	1年以下	1～5年	5年以上	合計
非衍生金融負債				
無附息負債	$ 8,128,408	$ -	$ -	$ 8,128,408
租賃負債	301,111	2,452,181	2,480,436	5,233,728
浮動利率工具	5,539,868	19,414,805	923,800	25,878,473
固定利率工具	15,575	880,833	-	896,408
	$ 13,984,962	$ 22,747,819	$ 3,404,236	$ 40,137,017

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1年以內	1～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上
租賃負債	$ 301,111	$ 2,452,181	$ 1,361,842	$ 481,923	$ 442,115	$ 194,556

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

(2) 衍生金融負債之流動性及利率風險表

針對衍生金融工具之流動性分析，就採淨額交割之衍生工具而言，係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製；就採總額交割之衍生工具而言，係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。

109 年 12 月 31 日

	0～3個月	4～6個月	7個月～1年	1至5年	5年以上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流出	($ 633,522)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流入	640,320	-	-	-	-
	$ 6,798	$ -	$ -	$ -	$ -

108 年 12 月 31 日

	0～3個月	4～6個月	7個月～1年	1至5年	5年以上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流出	($ 565,342)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流入	569,714	-	-	-	-
	$ 4,372	$ -	$ -	$ -	$ -

(3) 融資額度

	109年12月31日	108年12月31日
無擔保金融業及非金融業透支額度		
－已動用金額	$ 175,000	$ 525,000
－未動用金額	2,000,000	2,300,000
	$ 2,175,000	$ 2,825,000
有擔保金融業及非金融業透支額度		
－已動用金額	$23,637,001	$26,150,262
－未動用金額	29,847,000	2,466,000
	$53,484,001	$28,616,262

二七、關係人交易

本公司及子公司（係本公司之關係人）間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時全數予以銷除，故未揭露於本附註。除已於其他附註揭露外，本公司與其他關係人間之交易如下。

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
力晶公司	本公司之母公司（109年9月24日後為對本公司具重大影響力之公司）
黃崇仁	主要管理階層
吳明長	主要管理階層
林盈禎	主要管理階層
陳瑞隆	主要管理階層
謝再居	主要管理階層
童貴聰	主要管理階層
朱憲國	主要管理階層
謝明霖	主要管理階層
劉志能	主要管理階層
徐震球	主要管理階層（109年4月10日退休後為非關係人）
台灣光罩股份有限公司	實質關係人（109年9月24日後為非關係人）
智立投資股份有限公司	實質關係人（109年9月24日後為非關係人）
智豐科技股份有限公司	實質關係人
黃毓秀	實質關係人

（接次頁）

（承前頁）

關係人名稱	與本公司之關係
Zentel Japan Corporation	實質關係人
Powerchip Corporation Japan	實質關係人
財團法人力晶文化基金會	實質關係人
力晶積成電子製造股份有限公司職工福利委員會	實質關係人
世成科技股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為實質關係人）
智成電子股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為實質關係人）
合肥晶合集成電路有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為非關係人）
智仁科技開發股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為實質關係人）
世仁投資股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為對本公司具重大影響力之公司之合併個體）
力信投資股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為對本公司具重大影響力之公司之合併個體）
智典國際股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為對本公司具重大影響力之公司之合併個體）

(二) 營業收入

	109年度	108年度
實質關係人	$ 2,378,934	$ 1,656,474
關聯企業	-	214
	$ 2,378,934	$ 1,656,688

(三) 進　　貨

	109年度	108年度
母公司	$ -	$ 1,353

(四) 取得之不動產、廠房及設備

	取得價款	
	109年度	108年度
實質關係人	$ 1,001,080	$ -

(五) 銷貨成本－權利金

	109年度	108年度
關聯企業	$ 14,846	$ 18,900
實質關係人	4,807	-
	$ 19,653	$ 18,900

(六) 製造費用

	109年度	108年度
實質關係人	$ 289	$ 340

(七) 管理費用

	109年度	108年度
實質關係人	$ 24,672	$ 5,868
關聯企業	469	581
	$ 25,141	$ 6,449

(八) 研發費用

	109年度	108年度
實質關係人	$ 21,593	$ 206
關聯企業	17,885	101,712
	$ 39,478	$101,918

(九) 其他收益及費損淨額

	109年度	108年度
母 公 司	$ 1	$ -
主要管理階層	35	1
實質關係人	8,858	7,548
關聯企業	-	1,637
	$ 8,894	$ 9,186

(十) 應收帳款

	109年12月31日	108年12月31日
實質關係人	$253,494	$ 49,914

(十一) 向關係人借款（帳列長期借款）：

	109年12月31日	108年12月31日
實質關係人	$735,000	$ -

財務成本

	109年度	108年度
實質關係人	$ 9,533	$ -
關聯企業	-	1,641
	$ 9,533	$ 1,641

本公司向關係人借款之借款利率於 109 年 12 月 31 日為 1.80%。上列借款為擔保借款。

(十二) 合約負債

	109年12月31日	108年12月31日
實質關係人	$ 20,391	$ -

(十三) 其他應付款

	109年12月31日	108年12月31日
主要管理階層	$ -	$ 2,201
實質關係人	12,502	84
關聯企業	-	114,988
	$ 12,502	$117,273

(十四) 存出保證金

	109年12月31日	108年12月31日
主要管理階層	$ 1	$ 1
實質關係人	1	1
	$ 2	$ 2

本公司與關係人間晶圓代工之銷貨價格，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司支付關係人之權利金，本公司與關係人之進貨價格，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人間之取得之不動產、廠房及設備係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人之製造費用、管理費用及研發費用係依雙方議定之合作協議，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人間之其他收益及費損，係依據雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

流通在外之應收關係人款項未收取保證金或任何擔保品。

本公司合約負債之銷貨條件，係與客戶交易時參考市場行情，議定價格及數量。

上述之其他應付關係人款項主要係技術開發、權利金費用及利息費用產生。

除上述交易外，本公司與其他關係人間之交易，係按一般交易條件及價格辦理。

(十五) 承租協議

關係人類別／名稱	109年度	108年度
取得使用權資產		
實質關係人	$ -	$ 4,946

帳列項目	關係人類別／名稱	109年12月31日	108年12月31日
租賃負債－流動	主要管理階層	$ 81	$ 80
	實質關係人	12,251	2,619
	關聯企業	-	6,911
		$ 12,332	$ 9,610
租賃負債－非流動	主要管理階層	$ 165	$ 245
	實質關係人	24,831	1,916
	關聯企業	-	21,100
		$ 24,996	$ 23,261

帳列項目	關係人類別／名稱	109年度	108年度
財務成本	主要管理階層	$ 5	$ 9
	實質關係人	226	51
	關聯企業	558	898
		$ 789	$ 958

本公司向關係人承租辦公室、停車位及公務車，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金定期支付。

(十六) 主要管理階層薪酬

109 及 108 年度對董事及其他主要管理階層之薪酬總額如下：

	109年度	108年度
短期員工福利	$249,232	$160,996
退職後福利	38,227	22,723
	$287,459	$183,719

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、質抵押之資產

本公司下列資產已提供作為長期借款、天然氣使用、承租科管局土地及保稅品出區之擔保品：

	109年12月31日	108年12月31日
不動產、廠房及設備	$34,146,212	$27,454,063
受限制存款（帳列其他金融資產）	1,892,931	1,896,531
	$36,039,143	$29,350,594

二九、重大或有負債及未認列之合約承諾

除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

(一) 力積電公司分別於 92 年 8 月、94 年 3 月、97 年 6 月、99 年 3 月、10 月、100 年 7 月及 102 年 7 月與 Micron Memory Japan, Inc.（原 Elpida Memory Inc.）簽署若干動態隨機存取記憶體技術移轉與授權合約，力積電公司承諾自技術移轉完成後 5 年內支付一定金額之技術授權費及依約定產品之售價給付一定比例之權利金。惟雙方另於 100 年 5 月及 102 年 7 月簽署合作協議，修訂權利金支付比例。

(二) 力積電公司分別於 92 年 8 月及 94 年 3 月與某公司簽署若干動態隨機存取記憶體技術之專利授權合約，力積電公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(三) 力積電公司於 92 年 8 月與某公司等簽署若干動態隨機存取記憶體之專利技術授權合約，力積電公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(四) 力積電公司於 108 年 7 月與愛爾蘭商遠東金士頓公司簽訂代工合約至 110 年 10 月 31 日止，力積電公司承諾以約定價格為其製造記憶體產品。

三十、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本公司各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債資訊如下：

	109年12月31日			108年12月31日		
	外幣	匯率	帳面價值	外幣	匯率	帳面價值
外幣資產						
貨幣性項目						
美金	$ 361,840	28.372	$ 10,266,114	$ 225,938	30.046	$ 6,788,536
歐元	229	34.89	7,990	60	33.66	2,006
日幣	872,640	0.2751	240,063	1,594,271	0.2766	440,975
人民幣	3,059	4.34	13,275	3,006	4.31	12,955
外幣負債						
貨幣性項目						
美金	270,993	28.372	7,688,620	159,650	30.046	4,796,840
歐元	11,565	34.89	403,504	8,565	33.66	288,290
日幣	2,478,059	0.2751	681,714	2,407,362	0.2766	665,876

本公司主要承擔美金及新台幣之外幣匯率風險。以下資訊係按持有外幣個體之功能性貨幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等功能性貨幣換算至表達貨幣之匯率。具重大影響之外幣兌換損益（已實現及未實現）如下：

	109年度		108年度	
功能性貨幣	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益
新台幣	1（新台幣：新台幣）	($ 316,469)	1（新台幣：新台幣）	($ 68,070)

三一、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊：

1. 資金貸與他人。（無）
2. 為他人背書保證。（無）
3. 期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分）。（無）
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上。（無）
5. 取得不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上。（無）
6. 處分不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上。（無）
7. 與關係人進、銷貨之金額達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。（附表一）

8. 應收關係人款項達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。(附表二)

9. 從事衍生工具交易。(本公司從事衍生性商品相關資訊請參閱附註七及二六)

10. 被投資公司資訊、所在地區…等相關資訊。(附表三)

11. 其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額。(附表四)

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。(無)

2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益。(無)

(四) 主要股東資訊：股權比例達 5%以上之股東名稱、持股數額及比例。(附表五)

三二、部門資訊

(一) 部門收入、營運結果及部門資產

力積電公司及子公司之營運決策者用以分配資源及評量部門績效係著重於產品銷售之財務資訊，而每一產品皆具有相類似之經濟特性，每一產品使用類似之製程以生產類似之產品，且透過統一集中之銷售方式銷售，故力積電公司及子公司彙總為單一營運部門報導。另力積電公司及子公司提供給營運決策者複核之部門資訊，其衡量基礎與財務報表相同，故 109 及 108 年度應報導之部門收入及營運結果可參照 109 及 108 年度之合併綜合損益表；109 年及 108 年 12 月 31 日應報導之部門資產可參照 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表。

(二) 主要產品及勞務之收入

本公司之主要產品及勞務收入分析如下：

	109年度	108年度
包裝元件	$ 132,019	$ 382,834
晶　　圓	45,552,596	35,514,287
	$45,684,615	$35,897,121

(三) 地區別資訊

本公司來自外部客戶之收入依客戶所在國家區分與非流動資產按資產所在地區分之資訊列示如下：

	來自外部客戶之收入		非流動資產	
	109年度	108年度	109年12月31日	108年12月31日
台　　灣	$32,938,268	$23,480,915	$54,652,969	$51,994,057
中　　國	5,814,356	2,223,105	-	-
日　　本	1,700,875	1,487,232	4,989	4,556
其　　他	5,231,116	8,705,869	-	-
	$45,684,615	$35,897,121	$54,657,958	$51,998,613

非流動資產係不動產、廠房及設備、使用權資產及無形資產。

(四) 重要客戶資訊

來自單一客戶之收入達本公司收入之 10%以上者如下：

	109 年度		108 年度	
客戶名稱	金額	所佔比例%	金額	所佔比例%
甲公司	$ 7,721,858	17	$ 5,180,476	14
乙公司	4,468,525	10	3,118,477	9
丙公司	2,530,010	6	6,467,776	18

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

與關係人進、銷貨交易金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：新台幣仟元

進（銷）貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收（付）票據、帳款		備註
			進／銷貨	金額	佔總進／銷貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率	
力積電公司	智豐科技股份有限公司	實質關係人	銷貨	$ 1,472,901	3%	註 1	$ -	—	$ 151,421	2%	
	Zentel Japan Corporation	實質關係人	銷貨	903,134	2%	註 2	-	—	102,073	2%	

註 1： 主要係月結 60 天付款。

註 2： 主要係月結 30 天及貨到 30 天付款。

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

應收關係人款項達新臺幣1億元或實收資本額20%以上

民國109年12月31日

附表二

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
力積電公司	智豐科技股份有限公司	實質關係人	$ 151,421	19.45 次	$ -	—	$ 151,421	$ -
力積電公司	Zentel Japan Corporation	實質關係人	102,073	11.88 次	-	—	102,073	-

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

被投資公司資訊、所在地區...等相關資訊

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表三

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益
				本期期末	去年年底	股數（仟股）	比率（%）	帳面金額		
力積電公司	Global Powertec Co., Ltd.	英屬維京群島	從事各式投資業務	$ 1	$ 1	-	100.00	($ 78,244)	($ 20,719)	($ 20,719)
Global Powertec Co., Ltd.	PowerMemory Inc.	日本	從事半導體及電子零組件之開發及販售	703,165	703,165	500	100.00	8,380	(1,802)	(1,802)
	Maxram Inc.	日本	從事半導體及電子零組件之開發及販售	22,415	22,415	800	100.00	7,555	2,127	2,127

力晶積成電子製造有限公司及子公司

母子公司間及各子公司業務關係及重要交易往來情形

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表四

單位：新台幣仟元

交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係（註1）	交易往來情形			
			科目	金額	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率
力積電公司	PowerMemory 公司	1	研發費用	$ 87,325	註 2	-
力積電公司	Maxram 公司	1	研發費用	76,890	註 2	-

註 1： 1 係代表母公司對子公司之交易。

註 2： 係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

力晶積成電子製造股份有限公司

主要股東資訊

民國 109 年 12 月 31 日

附表五

主要股東名稱	股份	
	持有股數（股）	持股比例
力晶科技股份有限公司	825,691,640	26.59%

註 1： 本表主要股東資訊係由集保公司以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5%以上資料。本公司個體財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2： 上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10%之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

【附件三】

一一〇年度第三季合併財務報告及會計師查核報告

股票代碼：6770

力晶積成電子製造股份有限公司
及子公司

合併財務報告暨會計師核閱報告

民國 110 及 109 年第 3 季

地址：新竹科學工業園區新竹市力行一路18號

電話：(03)579-5000

§目　　錄§

項目	頁次	財務報告附註編號
一、封　面	1	-
二、目　錄	2	-
三、會計師核閱報告	3～4	-
四、合併資產負債表	5	-
五、合併綜合損益表	6	-
六、合併權益變動表	7	-
七、合併現金流量表	8～9	-
八、合併財務報表附註		
(一) 公司沿革	10	一
(二) 通過財務報告之日期及程序	10	二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	10～12	三
(四) 重大會計政策之彙總說明	12～13	四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	14	五
(六) 重要會計項目之說明	14～44	六～二六
(七) 關係人交易	44～48	二七
(八) 質抵押之資產	48	二八
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	49	二九
(十) 重大之災害損失	-	-
(十一) 重大之期後事項	-	-
(十二) 具重大影響之外幣資產及負債資訊	50～51	三十
(十三) 附註揭露事項		
1. 重大交易事項相關資訊	51～52、54～58	三一
2. 轉投資事業相關資訊	51～52、54～58	三一
3. 大陸投資資訊	52	三一
4. 主要股東資訊	59	三一
(十四) 部門資訊	52～53	三二

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師核閱報告

力晶積成電子製造股份有限公司　公鑒：

前　言

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國110年及109年9月30日之合併資產負債表，暨民國110年及109年7月1日至9月30日，以及民國110年及109年1月1日至9月30日之合併綜合損益表、民國110年及109年1月1日至9月30日之合併權益變動表與合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報表作成結論。

範　圍

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第六十五號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報表時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之人員查詢）、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

保留結論之基礎

如合併財務報表附註十所述，列入上開合併財務報表之非重要子公司之同期間財務報表未經會計師核閱，其民國110年及109年9月30日之資產總額分別為新台幣206,371仟元及223,685仟元，分別占合併資產總額之0.19%及0.29%；負債總額分別為新台幣263,891仟元及268,666仟元，分別占合併負債總額之0.49%及0.58%；其民國110年及109年7月1日至9月30日，以及民國110年及109年1月1日至9月30日之綜合損益總額分別為綜合(損)

益新台幣(43,411)仟元、(55,050)仟元、(140,191)仟元及(129,327)仟元，分別占合併綜合（損）益總額之(0.98)%、(7.88)%、(1.42)%及(4.75)%。另合併財務報表附註三一附註揭露所述轉投資事業之相關資訊，其與前述子公司有關之資訊亦未經會計師核閱。

保留結論

依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述該等子公司之財務報表倘經會計師核閱，對合併財務報表可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製，致無法允當表達力晶積成電子製造股份有限公司及子公司民國 110 年及 109 年 9 月 30 日之合併財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 7 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務績效，以及民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務績效及合併現金流量之情事。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　黃裕峰　　會計師　鍾鳴遠

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中華民國 110 年 10 月 19 日

力盈積[illegible]子公司

民國 110 年 9 月[illegible]日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	110年9月30日（經核閱）金額	%	109年12月31日（經查核）金額	%	109年9月30日（經核閱）金額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六及二六）	$ 26,980,089	25	$ 6,421,984	8	$ 5,877,774	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二六）	1,845	-	6,798	-	1,676	-
1170	應收帳款－非關係人淨額（附註八及二六）	8,766,864	8	5,981,210	8	6,143,027	8
1180	應收帳款－關係人淨額（附註八、二六及二七）	307,058	-	253,494	-	217,040	-
1200	其他應收款（附註二六）	337,185	-	241,097	-	270,022	-
130X	存貨（附註九）	8,318,236	8	7,818,611	10	7,822,278	10
1410	預付款項	546,718	1	379,415	1	497,815	1
1476	其他金融資產－流動（附註六、二六及二八）	707,931	1	567,931	1	567,931	1
1479	其他流動資產－其他	3,703	-	57,255	-	51,662	-
11XX	流動資產總計	45,969,629	43	21,727,795	28	21,449,225	27
	非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備（附註十一、十四、二四、二七及二八）	49,318,378	46	47,218,447	60	47,084,758	60
1755	使用權資產（附註十二及二七）	8,842,246	8	7,182,770	9	6,999,618	9
1780	無形資產（附註十三）	382,764	1	256,741	-	272,652	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	305,046	-	1,026,371	1	925,865	1
1915	預付設備款（附註二四）	573,805	1	90,063	-	68,965	-
1920	存出保證金（附註二六及二七）	45,190	-	7,687	-	6,612	-
1980	其他金融資產－非流動（附註六、二六及二八）	1,000,000	1	1,325,000	2	1,348,000	2
1990	其他非流動資產－其他（附註二四）	26,221	-	79,159	-	122	-
15XX	非流動資產總計	60,493,650	57	57,186,238	72	56,706,592	73
1XXX	資產總計	$106,463,279	100	$78,914,033	100	$78,155,817	100

代碼	負債及權益	110年9月30日（經核閱）金額	%	109年12月31日（經查核）金額	%	109年9月30日（經核閱）金額	%
	流動負債						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七及二六）	$ 9,099	-	$ -	-	$ 2,629	-
2130	合約負債－流動（附註十九及二七）	1,061,760	1	701,243	1	911,920	1
2170	應付帳款－非關係人（附註二六）	2,902,615	3	2,641,535	3	2,905,613	4
2213	應付設備款（附註二四及二六）	2,357,300	2	1,574,291	2	1,766,701	2
2219	其他應付款（附註十五、二六及二七）	5,968,054	5	4,210,771	5	3,903,137	5
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	-	-	300	-	4,863	-
2280	租賃負債－流動（附註十二、二四、二六及二七）	1,048,482	1	354,050	1	365,402	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十四、二四、二六及二八）	5,969,082	6	7,065,983	9	5,928,063	8
2399	其他流動負債－其他（附註十六、二四及二六）	2,144,321	2	1,089,901	1	1,338,963	2
21XX	流動負債總計	21,460,713	20	17,638,074	22	17,127,291	22
	非流動負債						
2540	長期借款（附註十四、二四、二六、二七及二八）	17,142,513	16	16,746,018	21	19,228,567	25
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	3,221,775	3	2,008,828	3	1,621,164	2
2580	租賃負債－非流動（附註十二、二四、二六及二七）	7,810,812	8	6,659,024	8	6,568,238	8
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	1,301,883	1	1,401,939	2	1,339,725	2
2645	存入保證金（附註二四及二六）	3,368,275	3	1,242,461	2	149,433	-
25XX	非流動負債總計	32,845,258	31	28,058,270	36	28,907,127	37
2XXX	負債總計	54,305,971	51	45,696,344	58	46,034,418	59
	權益（附註十八）						
3110	普通股股本	34,051,962	32	31,051,965	39	31,051,965	40
3200	資本公積	10,193,384	10	403,616	1	303,437	-
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	783,634	1	66,806	-	66,806	-
3320	特別盈餘公積	2,838	-	-	-	-	-
3350	未分配盈餘	7,128,769	6	1,695,690	2	699,627	1
3300	保留盈餘總計	7,915,241	7	1,762,496	2	766,433	1
3400	其他權益	(3,279)	-	(380)	-	(436)	-
3500	庫藏股票	-	-	(8)	-	-	-
3XXX	權益總計	52,157,308	49	33,217,689	42	32,121,399	41
	負債及權益總計	$106,463,279	100	$78,914,033	100	$78,155,817	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 10 月 19 日核閱報告）

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱靈琳

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

民國 110 年及 109 年 7 月 1 日至 9 月 30 日及 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

（僅經核閱，未依一般公認會計準則查核）

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼		110年7月1日至9月30日 金額	%	109年7月1日至9月30日 金額	%	110年1月1日至9月30日 金額	%	109年1月1日至9月30日 金額	%
4000	營業收入淨額（附註十九及二七）	$17,291,244	100	$11,583,844	100	$45,865,144	100	$33,811,273	100
5000	營業成本（附註九、二十及二七）	9,769,689	56	9,056,649	78	27,852,105	61	25,875,136	76
5900	營業毛利	7,521,555	44	2,527,195	22	18,013,039	39	7,936,137	24
	營業費用（附註二十及二七）								
6100	推銷費用	140,339	1	84,958	1	370,006	1	246,783	1
6200	管理費用	863,817	5	492,314	4	2,363,702	5	1,375,368	4
6300	研究發展費用	1,048,844	6	822,897	7	2,951,790	6	2,378,243	7
6000	營業費用合計	2,053,000	12	1,400,169	12	5,685,498	12	4,000,394	12
6500	其他收益及費損淨額（附註二十及二七）	15,321	-	58,092	-	223,751	-	109,624	-
6900	營業淨利	5,483,876	32	1,185,118	10	12,551,292	27	4,045,367	12
	營業外收入及支出								
7100	利息收入（附註二十）	11,336	-	5,291	-	22,128	-	23,529	-
7020	其他利益及損失（附註二十）	(5,060)	-	(120,009)	(1)	(215,329)	-	(135,819)	-
7050	財務成本（附註二十及二七）	(164,732)	(1)	(188,151)	(1)	(526,895)	(1)	(504,949)	(2)
7000	營業外收入及支出合計	(158,456)	(1)	(302,869)	(2)	(720,096)	(1)	(617,239)	(2)
7900	稅前淨利	5,325,420	31	882,249	8	11,831,196	26	3,428,128	10
7950	所得稅費用（附註四及二一）	907,279	5	183,881	2	1,939,201	4	704,478	2
8200	本期淨利	4,418,141	26	698,368	6	9,891,995	22	2,723,650	8
	其他綜合損益（附註十八）								
8360	後續可能重分類至損益之項目：								
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(441)	-	(18)	-	(2,899)	-	(142)	-
8300	本期其他綜合損益（稅後淨額）	(441)	-	(18)	-	(2,899)	-	(142)	-
8500	本期綜合損益總額	$ 4,417,700	26	$ 698,350	6	$ 9,889,096	22	$ 2,723,508	8
	每股盈餘（附註二二）								
9750	基本	$ 1.30		$ 0.22		$ 3.07		$ 0.88	
9850	稀釋	$ 1.18		$ 0.22		$ 2.77		$ 0.87	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 10 月 19 日核閱報告）

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

民國 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

（僅經核閱，未依一般公認審計準則查核）

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼		股本：股數（仟股）	股本：金額	資本公積：股票發行溢價	資本公積：受贈資產	資本公積：員工認股權	資本公積：合計	保留盈餘：法定盈餘公積	保留盈餘：特別盈餘公積	保留盈餘：未分配盈餘	其他權益項目：國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	權益總計
A1	109 年 1 月 1 日餘額	3,105,196	$ 31,051,965	$ 181,927	$ -	$ -	$ 181,927	$ 238,155	$ -	($ 1,595,372)	($ 294)	$ -	$ 29,876,381
	108 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	66,806	-	(66,806)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(600,000)	-	-	(600,000)
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	(238,155)	-	238,155	-	-	-
D1	109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	2,723,650	-	-	2,723,650
D3	109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(142)	-	(142)
D5	109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	2,723,650	(142)	-	2,723,508
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	121,510	121,510	-	-	-	-	-	121,510
Z1	109 年 9 月 30 日餘額	3,105,196	$ 31,051,965	$ 181,927	$ -	$ 121,510	$ 303,437	$ 66,806	$ -	$ 699,627	($ 436)	$ -	$ 32,121,399
A1	110 年 1 月 1 日餘額	3,105,196	$ 31,051,965	$ 181,927	$ 8	$ 221,681	$ 403,616	$ 66,806	$ -	$ 1,695,690	($ 380)	($ 8)	$ 33,217,689
	109 年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	716,828	-	(716,828)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	2,838	(2,838)	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,739,245)	-	-	(3,739,245)
C3	因受領贈與產生者	-	-	-	166,200	-	166,200	-	-	-	-	-	166,200
D1	110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	9,891,995	-	-	9,891,995
D3	110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,899)	-	(2,899)
D5	110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	9,891,995	(2,899)	-	9,889,096
E1	現金增資	300,000	3,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000
L3	庫藏股票註銷	-	(3)	-	-	-	-	-	-	(5)	-	8	-
N1	股份基礎給付交易	-	-	147,213	-	476,355	623,568	-	-	-	-	-	623,568
Z1	110 年 9 月 30 日餘額	3,405,196	$ 34,051,962	$ 9,329,140	$ 166,208	$ 698,036	$ 10,193,384	$ 783,634	$ 2,838	$ 7,128,769	($ 3,279)	$ -	$ 52,157,308

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 10 月 19 日核閱報告）

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

（僅經核閱，未依一般公認審計準則查核）

單位：新台幣仟元

代　碼		110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	$11,831,196	$ 3,428,128
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,568,713	4,359,145
A20200	攤銷費用	66,115	97,656
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失	14,052	5,325
A20900	財務成本	526,895	504,949
A21200	利息收入	(22,128)	(23,529)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	623,568	121,510
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	(123,211)	(11,002)
A23700	存貨呆滯及跌價回升利益	(306,568)	(317,725)
A24100	外幣兌換淨利益	(152,954)	(166,495)
A29900	退款負債（迴轉）提列數	(2,000)	36,000
A29900	押金設算利息收入	36	37
A29900	其　他	-	(23)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款（含關係人）	(2,839,218)	(965,183)
A31180	其他應收款	(167,358)	210,579
A31200	存　貨	(193,057)	(1,119,055)
A31230	預付款項	(168,843)	182,876
A31240	其他流動資產	53,552	140,553
A32125	合約負債	339,364	75,057
A32150	應付帳款	261,080	322,166
A32180	其他應付款	1,785,371	72,258
A32230	其他流動負債	(33,823)	(238,163)
A32240	淨確定福利負債－非流動	(100,056)	(105,002)
A33000	營運產生之淨現金流入	15,960,726	6,610,062
A33100	收取之利息	14,243	24,731
A33500	退還（支付）之所得稅	21,239	(6,756)
AAAA	營業活動之淨現金流入	15,996,208	6,628,037

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	($ 5,995,031)	($ 1,596,897)
B02800	處分不動產、廠房及設備	245,846	15,284
B03700	存出保證金增加	(37,514)	(355)
B03800	存出保證金減少	10	1,831
B04500	取得無形資產	(199,533)	(57,658)
B06500	其他金融資產減少（增加）	185,000	(19,400)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(5,801,222)	(1,657,195)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	100,000	300,000
C00200	短期借款減少	(100,000)	(300,000)
C01600	舉借長期借款	4,512,800	1,898,000
C01700	償還長期借款	(5,210,300)	(4,167,401)
C03000	存入保證金增加	4,584,110	408,476
C03100	存入保證金減少	(1,170,100)	(103,962)
C04020	租賃負債本金償還	(346,123)	(289,842)
C04500	發放現金股利	(3,739,245)	(600,000)
C04600	現金增資	12,000,000	-
C05600	支付之利息	(431,324)	(409,842)
C09900	受領股東贈與	166,200	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	10,366,018	(3,264,571)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,899)	(142)
EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	20,558,105	1,706,129
E00100	期初現金及約當現金餘額	6,421,984	4,171,645
E00200	期末現金及約當現金餘額	$26,980,089	$ 5,877,774

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 10 月 19 日核閱報告）

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

合併財務報告附註

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

（僅經核閱，未依一般公認審計準則查核）

（除另註明外，金額以新台幣仟元為單位）

一、公司沿革

力晶積成電子製造股份有限公司（以下稱「力積電公司」），係由力晶科技股份有限公司（以下稱「力晶公司」）分割設立，以 97 年 4 月 1 日為分割基準日，並經科學工業園區管理局核准設立。主要營業項目為從事各式積體電路之研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工及銷售。力積電公司及其子公司以下合稱「本公司」。

力晶公司於 109 年 6 月辦理減資，將所持有之力積電公司股票抵充應退還之減資股款，致力晶公司對力積電公司持股比例由 87.12%降至 26.82%，對力積電公司具有重大影響力。

力積電公司股票自 109 年 12 月起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。

本合併財務報告係以力積電公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告於 110 年 10 月 19 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動。

(二) 111 年適用之金管會認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日
「IFRSs 2018-2020 之年度改善」	2022 年 1 月 1 日（註 1）
國際財務報導準則第 3 號之修正「對觀念架構之引述」	2022 年 1 月 1 日（註 2）
國際會計準則第 16 號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	2022 年 1 月 1 日（註 3）
國際會計準則第 37 號之修正「虧損性合約－履行合約之成本」	2022 年 1 月 1 日（註 4）

註 1： 國際財務報導準則第 9 號之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間所發生之金融負債之交換或條款修改；國際會計準則第 41 號「農業」之修正適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間之公允價值衡量；國際財務報導準則第 1 號「首次採用 IFRSs」之修正係追溯適用於 2022 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間。

註 2： 收購日在年度報導期間開始於 2022 年 1 月 1 日以後之企業合併適用此項修正。

註 3： 於 2021 年 1 月 1 日以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備適用此項修正。

註 4： 於 2022 年 1 月 1 日尚未履行所有義務之合約適用此項修正。

截至本合併財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註 1)
國際財務報導準則第 10 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未　定
國際財務報導準則第 17 號「保險合約」	2023 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 17 號之修正	2023 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「負債分類為流動或非流動」	2023 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「會計政策之揭露」	2023 年 1 月 1 日（註 2）

（接次頁）

（承前頁）

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB發布之生效日(註1)
國際會計準則第8號之修正「會計估計之定義」	2023年1月1日（註3）
國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	2023年1月1日（註4）

註1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

註2：於2023年1月1日以後開始之年度報導期間推延適用此項修正。

註3：於2023年1月1日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計變動及會計政策變動適用此項修正。

註4：除於2022年1月1日就租賃及除役義務之暫時性差異認列遞延所得稅外，該修正係適用於2022年1月1日以後所發生之交易。

截至本合併財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有 IFRSs 揭露資訊。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。歷史成本通常係依取得資產所支付對價之公允價值決定。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

(三) 合併基礎

本合併財務報告係包含力積電公司及由力積電公司所控制個體（子公司）之財務報告。合併綜合損益表已納入被收購或被處分子公司於當期自收購日起或至處分日止之營運損益。子公司之財務報告已予調整，以使其會計政策與力積電公司之會計政策一致。於編製合併財務報告時，各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。子公司之綜合損益總額係歸屬至力積電公司業主及非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。

子公司明細、持股比率及營業項目，參閱附註十及附表四。

(四) 其他重大會計政策

除下列說明外，請參閱 109 年度合併財務報告之重大會計政策彙總說明。

1. 確定福利退職後福利

期中期間之退休金成本係採用前一年度結束日依精算決定之退休金成本率，以年初至當期末為基礎計算，並針對本期之重大市場波動，及重大計畫修正、清償或其他重大一次性事項加以調整。

2. 所得稅

所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。期中期間之所得稅係以年度為基礎進行評估，以預期年度總盈餘所適用之稅率，就期中稅前利益予以計算。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本合併財務報告所採用之重大會計判斷、估計及假設不確定性主要來源請參閱 109 年度合併財務報告。

本公司已將新型冠狀病毒肺炎疫情近期在我國之發展及對經濟環境可能之影響，納入對現金流量推估、成長率、折現率、獲利能力等相關重大會計估計之考量，管理階層將持續檢視估計與基本假設。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

六、現金及約當現金

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
活期存款	$ 14,070,716	$ 3,649,874	$ 4,114,082
支票存款	54,009	19,044	15,473
庫存現金	85	54	109
約當現金			
銀行定期存款	14,563,210	4,645,943	3,664,041
	28,688,020	8,314,915	7,793,705
受限制存款（帳列其他金融資產）	(1,707,931)	(1,892,931)	(1,915,931)
合　　計	$ 26,980,089	$ 6,421,984	$ 5,877,774

銀行存款於資產負債表日之市場利率區間如下：

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
銀行存款	0%~2.25%	0%~2.40%	0%~2.45%

七、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
金融資產－流動			
強制透過損益按公允價值衡量			
衍生工具			
－遠期外匯合約	$ 1,845	$ 6,798	$ 1,676
金融負債－流動			
持有供交易			
衍生工具			
－遠期外匯合約	$ 9,099	$ -	$ 2,629

於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下：

	幣別	到期期間	合約金額（仟元）
110年9月30日			
賣出遠期外匯	美金兌日圓	110.10.07~110.10.28	USD 9,940/ JPY 1,100,000
	美金兌新台幣	110.10.04~110.12.08	USD 76,000/ NTD 2,112,176
109年12月31日			
賣出遠期外匯	美金兌日圓	110.01.07~110.02.08	USD 22,553/ JPY 2,350,000
109年9月30日			
賣出遠期外匯	美金兌日圓	109.10.07~109.11.25	USD 31,303/ JPY 3,300,000

本公司從事遠期外匯交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。

八、應收帳款

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
按攤銷後成本衡量			
應收帳款－非關係人	$ 8,766,864	$ 5,981,210	$ 6,143,027
減：備抵損失	-	-	-
	8,766,864	5,981,210	6,143,027
應收帳款－關係人	307,058	253,494	217,040
減：備抵損失	-	-	-
	307,058	253,494	217,040
應收帳款淨額	$ 9,073,922	$ 6,234,704	$ 6,360,067

本公司對商品銷售之平均授信期間為月結30～60天，應收帳款不予計息。為減輕信用風險，本公司管理階層依公司相關之政策、程序及內部控制，指派專責團隊負責授信作業及其他監控程序，以確保逾期應收帳款之回收已採取適當行動，並按權責由管理階層負責授信額度之決定及授信核准。此外，本公司會定期逐一複核應收帳款之可回收金額以確保無法回收之應收帳款項已提列適當減損損失。

本公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量GDP預測及產業展望。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期，本公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

110 年 9 月 30 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期 超過 90 天	合計
總帳面金額	$8,839,819	$ 234,103	$ -	$ -	$ -	$9,073,922
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$8,839,819	$ 234,103	$ -	$ -	$ -	$9,073,922

109 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期 超過 90 天	合計
總帳面金額	$6,101,702	$ 125,424	$ 7,578	$ -	$ -	$6,234,704
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$6,101,702	$ 125,424	$ 7,578	$ -	$ -	$6,234,704

109 年 9 月 30 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期 超過 90 天	合計
總帳面金額	$6,164,155	$ 194,884	$ 1,028	$ -	$ -	$6,360,067
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$6,164,155	$ 194,884	$ 1,028	$ -	$ -	$6,360,067

九、存　　貨

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
製成品	$ 266,342	$ 598,004	$ 607,263
在製品	4,853,693	4,443,891	4,327,812
原料	3,198,201	2,776,716	2,887,203
	$ 8,318,236	$ 7,818,611	$ 7,822,278

與存貨相關之營業成本組成項目如下：

	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
銷貨成本	$ 9,769,689	$ 9,056,649	$27,852,105	$25,875,136
提列存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	($ 99,582)	$ 107,195	($ 306,568)	($ 317,725)
未攤銷固定製造費用	$ 12,623	$ 61,221	$ 53,125	$ 217,415

存貨呆滯及跌價回升利益，主係因產品價格回升與呆滯存貨出售及報廢所致。

十、子公司

列入合併財務報告之子公司

本合併財務報告編製主體如下：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比 110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
力積電公司	Global Powertec Co., Ltd.（Global Powertec 公司）	各項投資業務	100%	100%	100%
Global Powertec 公司	PowerMemory Inc.（PowerMemory 公司）	半導體及各式電子產品開發、製造、銷售及輸出入	100%	100%	100%
	Maxram Inc.（Maxram 公司）	半導體及各式電子產品開發、製造、銷售及輸出入	100%	100%	100%

上述列入合併財務報告之子公司，皆屬非重要子公司，其財務報告未經會計師核閱。

十一、不動產、廠房及設備

自　用

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
自　用	$ 49,318,378	$ 47,218,447	$ 47,084,758
房屋及建築	$ 4,025,026	$ 4,189,877	$ 4,215,903
機器設備	33,006,387	33,930,415	32,508,116
研發設備	2,740,359	1,685,369	1,757,126
廠務設備	6,366,925	6,415,656	6,502,580
運輸設備	3,965	2,156	2,297
生財器具	97,016	89,839	100,820
租賃改良	3,927	3,622	2,678
其他設備	62,383	85,574	94,689
待驗設備及未完工程	3,012,390	815,939	1,900,549
	$ 49,318,378	$ 47,218,447	$ 47,084,758

	110年1月1日至9月30日					
	期初餘額	增加	出售或報廢	淨兌換差額	科目移轉	期末餘額
成本						
房屋及建築	$ 11,691,104	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,691,104
機器設備	211,955,767	-	(2,922,846)	-	2,441,838	211,474,759
研發設備	3,181,892	-	(34,189)	-	1,188,029	4,335,732
廠務設備	31,793,949	-	(9,177)	-	377,382	32,162,154
運輸設備	11,699	-	-	-	2,329	14,028
生財器具	670,171	-	(7,166)	(264)	41,385	704,126
租賃改良	4,611	917	-	(483)	-	5,045
其他設備	1,895,965	-	(442)	-	13,429	1,908,952
	261,205,158	$ 917	($ 2,973,820)	($ 747)	$ 4,064,392	262,295,900

（接次頁）

（承前頁）

	110年1月1日至9月30日					
	期初餘額	增加	出售或報廢	淨兌換差額	科目移轉	期末餘額
累計折舊						
房屋及建築	$ 7,501,227	$ 164,851	$ -	$ -	$ -	$ 7,666,078
機器設備	177,987,219	3,303,314	(2,876,321)	-	16,058	178,430,270
研發設備	1,496,523	149,097	(34,189)	-	(16,058)	1,595,373
廠務設備	25,378,293	425,843	(8,907)	-	-	25,795,229
運輸設備	9,543	520	-	-	-	10,063
生財器具	580,332	34,101	(7,166)	(157)	-	607,110
租賃改良	989	234	-	(105)	-	1,118
其他設備	1,810,391	36,620	(442)	-	-	1,846,569
	214,764,517	$ 4,114,580	($ 2,927,025)	($ 262)	$ -	215,951,810
累計減損						
機器設備	38,133	$ -	($ 31)	$ -	$ -	38,102
待驗設備及未完工程	815,939	$ 6,260,843	$ -	$ -	($ 4,064,392)	3,012,390
淨額	$ 47,218,447					$ 49,318,378

	109年1月1日至9月30日					
	期初餘額	增加	出售或報廢	淨兌換差額	科目移轉	期末餘額
成本						
房屋及建築	$ 11,660,693	$ -	$ -	$ -	$ 1,200	$ 11,661,893
機器設備	207,574,333	-	(1,993,063)	-	4,179,713	209,760,983
研發設備	3,017,271	-	(20,235)	-	(5,860)	2,991,176
廠務設備	31,064,913	-	-	-	684,954	31,749,867
運輸設備	11,699	-	-	-	-	11,699
生財器具	634,368	179	(15,599)	(14)	52,029	670,963
租賃改良	3,598	-	-	(18)	-	3,580
其他設備	1,854,885	-	(1,104)	-	36,158	1,889,939
	255,821,760	$ 179	($ 2,030,001)	($ 32)	$ 4,948,194	258,740,100
累計折舊						
房屋及建築	7,280,572	$ 165,418	$ -	$ -	$ -	7,445,990
機器設備	175,883,873	3,253,879	(1,964,485)	-	41,467	177,214,734
研發設備	1,179,458	116,302	(20,235)	-	(41,475)	1,234,050
廠務設備	24,857,787	390,792	-	-	(1,292)	25,247,287
運輸設備	8,980	422	-	-	-	9,402
生財器具	552,298	33,442	(15,599)	(6)	8	570,143
租賃改良	739	167	-	(4)	-	902
其他設備	1,734,433	60,629	(1,104)	-	1,292	1,795,250
	211,498,140	$ 4,021,051	($ 2,001,423)	($ 10)	$ -	213,517,758
累計減損						
機器設備	38,587	$ -	($ 454)	$ -	$ -	38,133
待驗設備及未完工程	3,077,815	$ 3,770,928	$ -	$ -	($ 4,948,194)	1,900,549
淨額	$ 47,362,848					$ 47,084,758

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

房屋及建築	21至40年
機器設備	1.5至19年
研發設備	1.5至19年
廠務設備	6至30年
運輸設備	6年
生財器具	2至7年
租賃改良	4至16年
其他設備	4至6年

本公司設定質押作為借款擔保之不動產、廠房及設備金額，請參閱附註十四及二八。

十二、租賃協議

(一) 使用權資產

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
使用權資產帳面金額			
土　地	$ 2,029,647	$ 2,087,674	$ 2,109,344
建 築 物	113,612	138,400	146,394
機器設備	6,686,172	4,941,786	4,726,055
運輸設備	12,815	14,910	17,825
	$ 8,842,246	$ 7,182,770	$ 6,999,618

	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
使用權資產之增添			$ 2,114,684	$ 2,955,658
使用權資產之折舊費用				
土　地	$ 23,067	$ 21,670	$ 68,270	$ 56,868
建 築 物	7,904	7,994	23,712	23,981
機器設備	129,514	98,295	353,447	248,189
運輸設備	2,751	2,916	8,704	9,056
	$ 163,236	$ 130,875	$ 454,133	$ 338,094

(二) 租賃負債

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
租賃負債帳面金額			
流　動	$ 1,048,482	$ 354,050	$ 365,402
非 流 動	$ 7,810,812	$ 6,659,024	$ 6,568,238

租賃負債之折現率區間如下：

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
土　地	1.76%~3.74%	2.92%~3.74%	2.92%~3.74%
建 築 物	1.76%~2.64%	1.79%~2.64%	1.79%~2.64%
機器設備	1.61%~4.58%	1.61%~4.58%	1.83%~4.58%
運輸設備	1.76%~1.97%	1.77%~1.97%	1.77%~1.97%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租若干土地及建築物做為廠房及辦公室使用，土地主要租賃期間為 20 年。位於科學園區之土地租賃約定每 2 年依公告地價調整租賃給付。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之土地及建築物並無優惠承購權。

本公司承租若干機器設備以供營業使用，租賃期間為10年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之機器設備並無優惠承購權。

本公司另以融資租賃方式承租若干機器設備，租賃期間為 2.8年～6.2年。於租賃期間屆滿時，該機器設備所有權自動移轉為本公司所有。本公司之融資租賃義務係以出租人保有租賃資產之所有權作為擔保。

本公司承租若干公務車以供營業使用，租賃期間為3～4年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之公務車並無優惠承購權。

(四) 其他租賃資訊

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
短期租賃費用	$ 16,804	$ 2,867	$ 31,659	$ 7,986
租賃之現金流出總額 （含使用權資產）			$ 477,888	$ 367,294

本公司選擇對符合短期租賃之土地、辦公場地、機器設備與公務車租賃適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

十三、無形資產

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
技術移轉及授權費	$ 92,830	$ 110,606	$ 123,293
專 利 權	92,947	117,507	113,694
電腦軟體設備及系統費	33,070	18,841	25,230
其　　他	163,917	9,787	10,435
	$ 382,764	$ 256,741	$ 272,652

	技術移轉及授權費	電腦軟體設備及系統費	專利權	其他	合計
成　本					
110年1月1日餘額	$ 118,507	$ 52,859	$ 319,550	$ 15,116	$ 506,032
增　添	-	35,791	-	156,403	192,194
本期攤提完畢	-	(32,118)	-	-	(32,118)
淨兌換差額	-	(79)	-	-	(79)
110年9月30日餘額	$ 118,507	$ 56,453	$ 319,550	$ 171,519	$ 666,029

（接次頁）

（承前頁）

	技術移轉及授權費	電腦軟體設備及系統費	專利權	其他	合計
累計攤銷					
110年1月1日餘額	$ 7,901	$ 34,018	$ 202,043	$ 5,329	$ 249,291
攤銷費用	17,776	21,506	24,560	2,273	66,115
本期攤提完畢	-	(32,118)	-	-	(32,118)
淨兌換差額	-	(23)	-	-	(23)
110年9月30日餘額	$ 25,677	$ 23,383	$ 226,603	$ 7,602	$ 283,265
110年9月30日淨額	$ 92,830	$ 33,070	$ 92,947	$ 163,917	$ 382,764
成本					
109年1月1日餘額	$1,324,100	$ 68,488	$ 307,550	$ 8,967	$1,709,105
增添	118,507	2,539	-	7,443	128,489
本期攤提完畢	(1,121,250)	(10,788)	-	-	(1,132,038)
淨兌換差額	-	(2)	-	-	(2)
109年9月30日餘額	$ 321,357	$ 60,237	$ 307,550	$ 16,410	$ 705,554
累計攤銷					
109年1月1日餘額	$1,268,224	$ 23,308	$ 171,096	$ 4,657	$1,467,285
攤銷費用	51,090	22,488	22,760	1,318	97,656
本期攤提完畢	(1,121,250)	(10,788)	-	-	(1,132,038)
淨兌換差額	-	(1)	-	-	(1)
109年9月30日餘額	$ 198,064	$ 35,007	$ 193,856	$ 5,975	$ 432,902
109年9月30日淨額	$ 123,293	$ 25,230	$ 113,694	$ 10,435	$ 272,652

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

技術移轉及授權費	5年
電腦軟體設備及系統費	2至5年
專利權	5至15年
其他	2至5年

十四、借款

長期借款

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
擔保借款			
一長期抵押聯合貸款(一)	$ -	$ 15,058,180	$ 16,310,250
一長期抵押聯合貸款(二)	3,601,586	4,199,384	4,234,580
一長期抵押聯合貸款(三)	2,660,162	2,779,137	2,761,500
一長期抵押聯合貸款(四)	16,749,847	-	-

（接次頁）

（承前頁）

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
一關係人借款（參閱附註二七）	$ -	$ 735,000	$ 735,000
一其　他	-	865,300	865,300
小　計	23,011,595	23,637,001	24,906,630
無擔保借款			
一銀行借款	100,000	175,000	250,000
	23,111,595	23,812,001	25,156,630
減：列為1年內到期部分	(5,969,082)	(7,065,983)	(5,928,063)
長期借款	$ 17,142,513	$ 16,746,018	$ 19,228,567

力晶公司於107年3月14日簽署長期抵押聯合貸款(一)之授信合約、分別於107年12月10日、108年12月25日及109年5月29日簽署第一次、第二次及第三次增補合約，授信額度變更為新臺幣24,500,000仟元。依聯貸合約約定按季還本，到期日為112年12月，109年12月31日及109年9月30日有效利率分別為1.79%及2.04%。主要承諾事項如下：

(一) 力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，將聯合授信合約下之權利義務，於收購讓與基準日（即108年5月1日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，本授信案由力積電公司擔任借款人。

(二) 力積電公司需於額度管理銀行開立營運收支專戶該專戶之餘額應於每季末檢視當季累積存（匯）入金額不得低於新台幣6,000,000仟元或等值外幣。

(三) 力積電公司於本授信案期間，每年資本支出加計非資本支出及現金股利之支出限額，不得超逾前一年度之稅後淨利加計折舊並扣除特別保留份額。非資本支出，係指包括借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款及與借款人本業相關之長、短期投資股票或股權支出。但借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款屬借新還舊者不在此限。前述支出限額，依第二次增補合約規定，109年為一固定限額，自110年起則不得超逾前一期期末之稅後淨利減除重大無現金流量之收入，加計折舊並扣除特別保留份額。

(四) 力積電公司於本授信案期間，每季需提供經額度管理銀行同意之會計師就資本支出、支出限額及相關約定之查核或檢核報告予額度管理銀行。

(五) 於債務清償前，力積電公司之年度合併財務報表受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之限制。惟該借款已於 110 年 1 月提前清償完畢。

長期抵押聯合貸款(二)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 114 年 1 月，截至 110 年 9 月 30 日、109 年 12 月 31 日及 109 年 9 月 30 日有效利率分別為 1.79%、1.87%及 1.87%。另貸款合約規定，力積電公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有負債比率、流動比率及利息保障倍數等限制。

長期抵押聯合貸款(三)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 113 年 2 月，截至 110 年 9 月 30 日、109 年 12 月 31 日及 109 年 9 月 30 日有效利率分別為 1.79%、1.87%及 1.87%。另貸款合約規定，力積電公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有負債比率、流動比率及利息保障倍數等限制。

長期抵押聯合貸款(四)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 115 年 1 月，截至 110 年 9 月 30 日有效利率為 1.79%。主要承諾事項如下：

(一) 力積電公司於本授信案期間，每期資本支出加計非資本支出及現金股利之支出限額，不得超逾前一期期末之稅後淨利減除重大無現金流量之收入，加計折舊並扣除特別保留份額。惟依合約另有約定者，不計入支出限額，非資本支出，係指包括借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款及與借款人本業相關之長、短期投資股票或股權支出。但借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款屬借新還舊者不在此限。

(二) 力積電公司於本授信期間，每季須提供經額度管理銀行同意之會計師資本支出、支出限額及相關約定之查核或檢核報告予額度管理銀行。

(三) 於債務清償前，力積電公司之年度合併財務報表受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之限制。

長期借款擔保之情形，請參閱附註二八。

力晶公司分別於 106 年 9 月及 106 年 12 月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約約定按季還本，到期日為 109 年 9 月至 109 年 12 月。力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於 108 年 4 月簽署中長期授信增補合約，將授信合約下之債務、權利及義務，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，前述無擔保銀行中長期額度貸款由力積電公司擔任借款人。截至 109 年 12 月止，前述中長期借款已清償完畢。

力積電公司分別於 108 年 5 月及 108 年 7 月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約規定每半年還本，到期日為 111 年 5 月及 110 年 7 月，年利率分別為 1.35%及 1.32%。前述部分借款已於 110 年 7 月屆期清償完畢。

關係人借款：力積電公司於 109 年 3 月與關係人簽訂設備買賣融資借款，依合約約定按季付息，相關款項於到期日 111 年 4 月付清，惟前述借款已於 110 年 7 月提前清償完畢。關係人交易請參閱附註二七。擔保之情形請參閱附註二八。

其他借款：力晶公司於 106 年 5 月至 10 月與金士頓公司承作設備買賣融資借款，相關款項於到期日 108 年 10 月一次支付。依設備買賣融資需支付價款設算隱含利率約為 2.78%至 2.89%。力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予力積電公司，並自基準日起，本融資借款由力積電公司擔任借款人。前述借款於 108 年 9 月簽署增補合約，對方約定於 110 年 10 月一次清償借款。前述借款已於 110 年 7 月提前清償完畢。擔保之情形請參閱附註二八。

十五、其他應付款

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
應付員工及董事酬勞	$ 2,317,104	$ 542,871	$ 294,281
應付薪資及獎金	1,350,942	1,365,086	1,232,219
應付權利金	281,873	303,512	223,449
應付電費	252,750	193,478	247,754
應付利息	116,065	131,742	129,909
其　　他	1,649,320	1,674,082	1,775,525
	$ 5,968,054	$ 4,210,771	$ 3,903,137

十六、其他流動負債

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
存入保證金	$ 1,666,251	$ 415,357	$ 705,479
退款負債	188,000	190,000	227,000
其　　他	290,070	484,544	406,484
	$ 2,144,321	$ 1,089,901	$ 1,338,963

十七、退職後福利計畫

110 年及 109 年 7 月 1 日至 9 月 30 日與 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日認列之確定福利計畫相關退休金費用係以 109 年及 108 年 12 月 31 日精算決定之退休金成本率計算，金額分別為 8,327 仟元、9,356 仟元、24,982 仟元及 28,069 仟元。

十八、權　　益

(一) 普通股股本

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
額定股數（仟股）	5,000,000	5,000,000	5,000,000
額定股本	$ 50,000,000	$ 50,000,000	$ 50,000,000
已發行且已收足股款之股數（仟股）	3,405,196	3,105,196	3,105,196
已發行股本	$ 34,051,962	$ 31,051,965	$ 31,051,965

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為 500,000 仟股。

力積電公司股本變動主要係因現金增資及庫藏股註銷。

力積電公司為配合擴充產能、提升生產製程及增進研發能力所需購置相關設備，於 110 年 3 月 9 日董事會決議，辦理現金增資發行新股 300,000 仟股，每股面額 10 元，以每股新台幣 40 元發行，發行後流通在外股數 3,405,196 仟股。本次以 110 年 6 月 11 日為增資基準日。

上述現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數之 10%由員工認購。

力積電公司於 110 年 10 月 19 日董事會決議，辦理現金增資發行新股 130,000 仟股，每股面額 10 元，暫定以每股新台幣 50 元發行，發行後流通在外股數 3,535,196 仟股。

上述現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數之 15%由員工認購。

(二) 資本公積

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)			
股票發行溢價	$ 9,170,680	$ 170,680	$ 170,680
受贈資產	166,208	8	-
僅得用以彌補虧損			
員工認股權執行轉入之金額	158,460	11,247	11,247
不得作為任何用途			
發行員工認股權	698,036	221,681	121,510
	$ 10,193,384	$ 403,616	$ 303,437

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利

依力積電公司章程之盈餘分派政策規定，力積電公司盈餘分派或虧損彌補得於每半會計年度終了後為之。每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達力積電公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴

轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後之。力積電公司章程規定之員工及董事酬勞分派政策，參閱附註二十之(七)員工酬勞及董事酬勞。

力積電公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中現金股利於股利總額之 10%～100%，股票股利於股利總額之 0%～90%。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

力積電公司於 109 年 5 月 27 日股東常會決議通過 108 年度虧損撥補案，以法定盈餘公積彌補虧損 238,155 仟元。

力積電公司於分配盈餘時，必須依法令規定就其他權益項目減項淨額（如國外營運機構財務報表換算之兌換差額累計餘額）提列特別盈餘公積。嗣後其他權益項目減項金額如有減少，可就減少金額自特別盈餘公積轉回未分配盈餘。

力積電公司於 109 年 7 月 28 日董事會決議 109 年上半年度盈餘分配案如下：

	109年1月1日 至6月30日
法定盈餘公積	$ 66,806
現金股利	$600,000
每股現金股利（元）	$ 0.19

力積電公司於 110 年 3 月 9 日舉行董事會決議通過 109 年下半年度盈餘分配案如下：

	109年7月1日 至12月31日
法定盈餘公積	$ 169,443
特別盈餘公積	$ 380
現金股利	$ 1,525,867
每股現金股利（元）	$ 0.49

上述現金股利已由董事會決議分配，並於 110 年 7 月 2 日召開股東常會報告，109 年度其餘盈餘分配項目業已於 110 年 7 月 2 日股東常會決議。

力積電公司於 110 年 8 月 9 日舉行董事會，決議通過 110 年上半年度盈餘分配案如下：

	110年1月1日 至6月30日
法定盈餘公積	$ 547,385
特別盈餘公積	$ 2,458
現金股利	$ 2,213,378
每股現金股利（元）	$ 0.65

(四) 其他權益項目

其他權益項目之變動數如下：

110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額
期初餘額	($ 380)
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額	(2,899)
期末餘額	($ 3,279)

109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額
期初餘額	($ 294)
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額	(142)
期末餘額	($ 436)

十九、營業收入

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
客戶合約收入				
商品銷貨收入	$17,291,244	$11,583,844	$45,865,144	$33,811,273

(一) 合約餘額

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日	109年1月1日
應收帳款（附註八）	$ 9,073,922	$ 6,234,704	$ 6,360,067	$ 5,394,884
合約負債				
商品銷售	$ 928,706	$ 623,901	$ 755,907	$ 808,913
其　　他	133,054	77,342	156,013	117,446
	$ 1,061,760	$ 701,243	$ 911,920	$ 926,359

來自年初合約負債於當期認列為收入之金額如下：

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
來自年初合約負債				
銷貨商品	$ 26,867	$ 59,973	$ 440,478	$ 494,394
其他（帳列其他收益及費損淨額）	21,220	-	31,800	1,862
	$ 48,087	$ 59,973	$ 472,278	$ 496,256

(二) 客戶合約收入之細分

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
主要地區市場				
台　　灣	$11,929,942	$ 8,097,080	$32,214,278	$24,327,528
中　　國	2,745,084	1,600,665	6,702,401	4,238,034
其　　他	2,616,218	1,886,099	6,948,465	5,245,711
	$17,291,244	$11,583,844	$45,865,144	$33,811,273
產品項目				
包裝元件	$ 5,712	$ 20,162	$ 24,919	$ 132,019
晶　　圓	17,285,532	11,563,682	45,840,225	33,679,254
	$17,291,244	$11,583,844	$45,865,144	$33,811,273

二十、本期淨利

(一) 其他收益及費損淨額

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益（損失）	($ 43,082)	$ 24,557	$ 123,211	$ 11,002
其他收入及支出	58,403	33,535	100,540	98,622
	$ 15,321	$ 58,092	$ 223,751	$ 109,624

(二) 利息收入

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
銀行存款	$ 11,324	$ 4,825	$ 22,092	$ 22,250
押金設算息	12	12	36	37
附買回債券	-	454	-	1,242
	$ 11,336	$ 5,291	$ 22,128	$ 23,529

(三) 其他利益及損失

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
外幣兌換淨（損失）利益	$ 72	($ 121,395)	($ 191,342)	($ 140,716)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（損失）利益	(5,132)	1,386	(23,987)	4,897
	($ 5,060)	($ 120,009)	($ 215,329)	($ 135,819)

(四) 財務成本

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
借款之利息	$ 102,929	$ 131,620	$ 350,671	$ 361,540
租賃負債之利息	59,364	54,011	168,773	135,951
其　　他	2,439	2,520	7,451	7,458
	$ 164,732	$ 188,151	$ 526,895	$ 504,949

利息資本化相關資訊如下：

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
利息資本化金額	$ 4,713	$ 6,068	$ 18,778	$ 33,651
利息資本化利率	2.08%~2.09%	2.23%~2.24%	2.06%~2.12%	1.98%~2.24%

(五) 折舊及攤銷

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
不動產、廠房及設備	$ 1,366,702	$ 1,356,666	$ 4,114,580	$ 4,021,051
使用權資產	163,236	130,875	454,133	338,094
無形資產	21,621	27,574	66,115	97,656
合　　計	$ 1,551,559	$ 1,515,115	$ 4,634,828	$ 4,456,801
折舊費用依功能別彙總				
營業成本	$ 1,408,747	$ 1,382,531	$ 4,229,232	$ 4,070,896
營業費用	121,191	105,010	339,481	288,249
	$ 1,529,938	$ 1,487,541	$ 4,568,713	$ 4,359,145

（接次頁）

（承前頁）

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
攤銷費用依功能別彙總				
營業成本	$ 13,241	$ 23,544	$ 40,814	$ 88,938
營業費用	8,380	4,030	25,301	8,718
	$ 21,621	$ 27,574	$ 66,115	$ 97,656

(六) 員工福利費用

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
退職後福利				
確定提撥計畫	$ 88,078	$ 81,967	$ 261,863	$ 244,305
確定福利計畫（附註十七）	8,327	9,356	24,982	28,069
	96,405	91,323	286,845	272,374
股份基礎給付				
權益交割	157,701	42,072	623,568	121,510
其他員工福利	3,581,148	2,289,337	9,453,170	6,658,317
員工福利費用合計	$ 3,835,254	$ 2,422,732	$10,363,583	$ 7,052,201
依功能別彙總				
營業成本	$ 2,403,668	$ 1,614,673	$ 6,486,160	$ 4,735,888
營業費用	1,431,586	808,059	3,877,423	2,316,313
	$ 3,835,254	$ 2,422,732	$10,363,583	$ 7,052,201

(七) 員工酬勞及董事酬勞

力積電公司係以當年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之力積電公司稅前淨利，應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

110 年及 109 年 7 月 1 日至 9 月 30 日與 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日估列之員工酬勞及董事酬勞如下：

金　　額

	110年7月1日至9月30日		109年7月1日至9月30日		110年1月1日至9月30日		109年1月1日至9月30日	
	現　金	股　票	現　金	股　票	現　金	股　票	現　金	股　票
員工酬勞	$ 973,895	$ -	$ 127,275	$ -	$1,891,868	$ -	$ 234,827	$ -
董事酬勞	194,779	-	31,819	-	424,272	-	58,707	-

年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

109年度員工酬勞及董事酬勞於110年3月9日經董事會決議如下：

金　　額

	109年度	
	現　　金	股　　票
員工酬勞	$482,131	$ -
董事酬勞	60,000	-

109年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發金額與109年度合併財務報告之認列金額並無差異。

力積電公司108年度係為稅前淨損，故不估列員工酬勞及董監事酬勞。

有關力積電公司董事會決議之員工酬勞及董事酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

二一、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅費用主要組成項目

	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
當期所得稅				
本期產生者	$ 654,027	$ 1,580	$ 1,112,289	$ 4,315
以前年度之調整	-	-	-	4,864
	654,027	1,580	1,112,289	9,179
遞延所得稅				
當期產生者	253,252	643,606	823,869	1,156,604
虧損扣抵	-	(461,305)	3,043	(461,305)
	253,252	182,301	826,912	695,299
認列於損益之所得稅費用	$ 907,279	$ 183,881	$ 1,939,201	$ 704,478

(二) 所得稅核定情形

力積電公司截至108年度以前之營利事業所得稅申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二二、每股盈餘

單位：每股元

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
基本每股盈餘	$ 1.30	$ 0.22	$ 3.07	$ 0.88
稀釋每股盈餘	$ 1.18	$ 0.22	$ 2.77	$ 0.87

用以計算每股盈餘及普通股加權平均股數如下：

本期淨利

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
用以計算基本及稀釋每股盈餘之淨利	$ 4,418,141	$ 698,368	$ 9,891,995	$ 2,723,650

股　　數

單位：仟股

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
用以計算基本每股盈餘之普通股加權平均股數	3,405,196	3,105,196	3,221,863	3,105,196
具稀釋作用潛在普通股之影響：				
員工酬勞	29,236	22,689	41,752	22,689
員工認股權	306,969	-	306,969	-
用以計算稀釋每股盈餘之普通股加權平均股數	3,741,401	3,127,885	3,570,584	3,127,885

若力積電公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

力積電公司將員工認股權憑證之潛在普通股列入計算110年及109年7月1日至9月30日與110年及109年1月1日至9月30日之稀釋每股盈餘時，因部分員工認股權憑證具反稀釋作用，故該部分未納入稀釋每股盈餘之股數計算。

二三、股份基礎給付協議

(一) 現金增資保留員工認股

力積電公司經董事會決議現金增資發行新股，並依據公司法保留新股總數 10%計 30,000 仟股由員工認購。員工認購不足一股之畸零股或放棄認股之股份，則授權董事長洽特定人認購之。

力積電公司於 110 年 4 月 20 日給與之員工認股權，其公平價值使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之參數如下：

衡量日每股股權公平價值	44.45 元
行使價格	40 元
預期波動率	38.89%
預期存續期間	0.08 年
預期股利率	-
無風險利率	0.14%
認股權公平價值	4.9071

力積電公司 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日因現金增資保留員工認購權利認列之酬勞成本為 147,213 仟元。

(二) 員工認股權計畫

力積電公司分別於 109 年 1 月 6 日及 109 年 11 月 10 日經金融監督管理委員會核准發行員工認股權 150,000 仟單位及 300,000 仟單位，每一單位可認購普通股 1 股。認股權之存續期間均為 6 年，憑證持有人於發行屆滿 2 年之日起，可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後，遇有力積電公司普通股股份發生變動時，認股權行使價格依規定公式予以調整。

員工認股權之相關資訊如下：

	109年認股權計畫		108年認股權計畫	
110年1月1日至9月30日	單位（仟）	加權平均執行價格（元）	單位（仟）	加權平均執行價格（元）
期初流通在外	268,503	$ 15.50	145,583	$ 10.44
本期給與	926	63.00	-	-
本期放棄	(6,694)	16.43	(2,853)	11.24
期末流通在外	262,735		142,730	
期末可執行	-		-	
本期給與之認股權加權平均公允價值（元）	$ 7.20		$ -	

109年1月1日至9月30日	108年認股權計畫 單位（仟）	加權平均執行價格（元）
期初流通在外	-	$ -
本期給與	138,440	10.00
本期放棄	(3,826)	10.00
期末流通在外	134,614	
期末可執行	-	
本期給與之認股權加權平均公允價值（元）	$ 3.35	

截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：

認股權計劃	110年9月30日 執行價格之範圍（元）	110年9月30日 加權平均剩餘合約年限（年）	109年12月31日 執行價格之範圍（元）	109年12月31日 加權平均剩餘合約年限（年）	109年9月30日 執行價格之範圍（元）	109年9月30日 加權平均剩餘合約年限（年）
109 年認股權計劃	$14.70~63.00	5.13	$15.50	5.88	$ -	-
108 年認股權計劃	$10.00~14.70	4.37	$10.00~15.50	5.13	$ 10.00	5.31

力積電公司於 109 年 1 月 20 日董事會通過 108 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	9.28 元
執行價格	10.00 元
預期波動率	42.70%
存續期間	4.87 年
預期股利率	-
無風險利率	0.53%
認股權公平價值	3.25~3.50

力積電公司於 109 年 11 月 13 日董事會通過 108 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	15.31 元
執行價格	15.50 元
預期波動率	42.58%
存續期間	4.88 年
預期股利率	2.41%
無風險利率	0.22%
認股權公平價值	4.72~4.85

力積電公司於 109 年 11 月 13 日董事會通過 109 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	15.31 元
執行價格	15.50 元
預期波動率	42.58%
存續期間	4.88 年
預期股利率	2.41%
無風險利率	0.22%
認股權公平價值	4.72~4.85

力積電公司於 110 年 3 月 9 日董事會通過 109 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	38.47 元
執行價格	66.50 元
預期波動率	43.30%
存續期間	4.95 年
預期股利率	2.27%
無風險利率	0.36%
認股權公平價值	6.98~7.53

110 年及 109 年 7 月 1 日至 9 月 30 日與 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日認列之酬勞成本分別為 157,701 仟元、42,072 仟元、476,355 仟元及 121,510 仟元。

二四、現金流量資訊

(一) 非現金交易

	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
不動產、廠房及設備增加數	$ 6,261,760	$ 3,771,107
應付設備款（增）減變動數	(783,009)	30,529
預付設備款增（減）變動數	483,742	(1,471,310)
其　　他	32,538	(733,429)
取得不動產、廠房及設備支付現金數	$ 5,995,031	$ 1,596,897

(二) 來自籌資活動之負債變動

110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

	110年1月1日	現金流量	非現金之變動 匯率變動	非現金之變動 其他（註）	110年9月30日
長期借款(含一年內到期之長期借款)	$ 23,812,001	($ 697,500)	$ -	($ 2,906)	$ 23,111,595
存入保證金	1,657,818	3,414,010	(37,302)	-	5,034,526
租賃負債	7,013,074	(346,123)	(68,435)	2,260,778	8,859,294
長期預付款(帳列其他非流動資產－其他)	79,159	-	-	(52,938)	26,221
	$ 32,562,052	$ 2,370,387	($ 105,737)	$ 2,204,934	$ 37,031,636

109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

	109年1月1日	現金流量	非現金之變動 匯率變動	非現金之變動 其他（註）	109年9月30日
長期借款(含一年內到期之長期借款)	$ 26,675,262	($ 2,269,401)	$ -	$ 750,769	$ 25,156,630
存入保證金	490,868	304,514	(29,904)	89,434	854,912
租賃負債	4,298,869	(289,842)	(130,841)	3,055,454	6,933,640
長期預付款(帳列其他非流動資產－其他)	6,748	-	-	(6,626)	122
	$ 31,471,747	($ 2,254,729)	($ 160,745)	$ 3,889,031	$ 32,945,304

註：其他包含包含來自客戶合約負債轉入、新增長期借款及租賃負債、借款及租賃負債財務成本，以及長期預付款轉列長期借款減項。

二五、資本風險管理

本公司進行資本管理係確保公司能夠於繼續經營之前提下，藉由調整債務與權益最適化，以達成股東權益極大化。

本公司資本結構係由本公司之淨債務（即借款減除現金及約當現金）及歸屬於母公司業主之權益（即股本、資本公積、保留盈餘及其他權益項目）組成。

二六、金融工具

(一) 公允價值之資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面價值趨近其公允價值。

(二) 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

110 年 9 月 30 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 1,845	$ -	$ 1,845
透過損益按公允價值衡量之金融負債				
衍生工具	$ -	$ 9,099	$ -	$ 9,099

109 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 6,798	$ -	$ 6,798

109 年 9 月 30 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 1,676	$ -	$ 1,676
透過損益按公允價值衡量之金融負債				
衍生工具	$ -	$ 2,629	$ -	$ 2,629

110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日無第 1 等級與第 2 等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 第 2 等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具－遠期外匯合約	現金流量折現法：按期末之可觀察遠期匯率及合約所訂匯率估計未來現金流量，並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

(三) 金融工具之種類

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
金融資產			
強制透過損益按公允價值衡量	$ 1,845	$ 6,798	$ 1,676
按攤銷後成本衡量之金融資產（註1）	38,144,317	14,798,403	14,430,406
金融負債			
透過損益按公允價值衡量			
持有供交易	9,099	-	2,629
按攤銷後成本衡量（註2）	48,233,384	40,909,490	41,520,633

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款－非關係人淨額、應收帳款－關係人淨額、其他應收款、其他金融資產及存出保證金等按攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含應付帳款－非關係人、應付設備款、其他應付款、一年內到期之長期借款、租賃負債、長期借款及存入保證金等以攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

本公司之財務風險管理目標，係為管理與營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本公司致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司對於前述財務風險管理已依相關規範建立適當之政策、程序及內部控制，重要財務活動須經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。公司恪遵相關財務操作程序。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）及利率變動風險（參閱下述(2)）。本公司從事衍生金融工具（包括遠期外匯）以管理所承擔之外幣匯率。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而產生匯率變動風險。本公司匯率風險之管理採部分自然避險，並於政策許可之範圍內，利用即期外匯交易及遠匯合約管理風險。本公司之匯率風險管理，以避險為目的，不以獲利為目的。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含合併財務報表中已沖銷之非功能性貨幣計價之貨幣性項目），參閱附註三十。

敏感度分析

本公司主要受到美金、日幣、歐元及人民幣匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少 1%時，本公司之敏感度分析。敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其期末之換算以匯率變動 1%予以調整。敏感度分析之範圍包括現金及約當現金、應收帳款（含關係人）、其他應收款、應付帳款、應付設備款、租賃負債、其他應付款及存入保證金。下表係表示當功能性貨幣相對於各相關貨幣貶值 1%時，將使稅前淨利增（減）之金額。

	美金之影響		日幣之影響		歐元之影響		人民幣之影響	
	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
損益	$ 44,128	$ 29,309	($ 976)	($ 7,249)	($ 3,487)	($ 3,890)	$ 134	$ 130

(2) 利率風險

因本公司內個體同時以固定及浮動利率借入資金，因而產生利率暴險。本公司定期評估避險活動，以確保採用最符合成本效益之避險策略。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
具公允價值利率風險			
一金融資產	$14,563,210	$ 4,645,943	$ 3,664,041
一金融負債	(8,859,294)	(8,613,374)	(8,533,940)
具現金流量利率風險			
一金融資產	14,070,716	3,649,874	4,114,082
一金融負債	(23,111,595)	(22,211,701)	(23,556,330)

敏感度分析

有關利率風險之敏感性分析，主要針對資產負債表日浮動利率金融負債之現金流量變動為計算基礎。

若利率增加／減少 0.1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之稅前淨利將分別減少／增加 6,781 仟元及 14,582 仟元，主因為本公司之浮動利率淨負債利率暴險。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務及本公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於資產負債表所認列之金融資產帳面金額。

為減輕信用風險，本公司已訂定授信及應收帳款管理辦法，以確保應收帳款之收回，以及逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司會定期逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。

本公司應收帳款之對象涵蓋眾多客戶，分散於不同產業及地理區域。本公司持續地針對應收帳款客戶之財務狀況每年或不定期進行評估。

個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、信評機構評等、本公司內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。本公司定期或不定期

針對應收帳款客戶之財務狀況進行評估，必要時亦會要求客戶提供預收貨款、保證金、質押定存或其他擔保品，以降低特定客戶的信用風險。

另因流動資金及衍生金融工具之交易對方係信用良好之銀行，故該信用風險係屬有限。

3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應集團營運並減輕現金流量波動之影響。

銀行借款對本公司而言係為一項主要流動性風險來源。截至 110 年 9 月 30 日暨 109 年 12 月 31 日及 9 月 30 日止，本公司未動用之融資額度參閱下列(3)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依本公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。因此，本公司可被要求立即還款之銀行借款，係列於下表最早之期間內，不考慮銀行立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

110 年 9 月 30 日

	1 年 以 下	1 ～ 5 年	5 年 以 上	合 計
非衍生金融負債				
無附息負債	$11,220,656	$ 7,313	$ -	$11,227,969
租賃負債	1,232,143	5,737,694	3,529,379	10,499,216
浮動利率工具	5,990,000	17,170,405	-	23,160,405
	$18,442,799	$22,915,412	$ 3,529,379	$44,887,590

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1 年 以 內	1 ～ 5 年	5 ～ 1 0 年	1 0 ～ 1 5 年	1 5 ～ 2 0 年	2 0 年 以 上
租賃負債	$ 1,232,143	$ 5,737,694	$ 1,678,306	$ 638,721	$ 552,472	$ 659,880

109 年 12 月 31 日

	1 年 以 下	1 ～ 5 年	5 年 以 上	合 計
非衍生金融負債				
無附息負債	$ 8,426,597	$ -	$ -	$ 8,426,597
租賃負債	494,973	4,412,787	3,817,566	8,725,326
浮動利率工具	6,223,468	16,034,137	-	22,257,605
固定利率工具	894,062	741,597	-	1,635,659
	$16,039,100	$21,188,521	$ 3,817,566	$41,045,187

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1年以內	1～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上
租賃負債	$ 494,973	$ 4,412,787	$ 1,870,684	$ 638,721	$ 572,376	$ 735,785

109年9月30日

	1年以下	1～5年	5年以上	合計
非衍生金融負債				
無附息負債	$ 8,575,451	$ -	$ -	$ 8,575,451
租賃負債	479,272	4,251,963	3,934,042	8,665,277
浮動利率工具	5,952,718	17,656,354	-	23,609,072
固定利率工具	28,763	1,614,114	-	1,642,877
	$15,036,204	$23,522,431	$ 3,934,042	$42,492,677

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1年以內	1～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上
租賃負債	$ 479,272	$ 4,251,963	$ 1,955,224	$ 638,721	$ 579,010	$ 761,087

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

(2) 衍生金融負債之流動性及利率風險表

針對衍生金融工具之流動性分析，就採淨額交割之衍生工具而言，係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製；就採總額交割之衍生工具而言，係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。

110年9月30日

	0～3個月	4～6個月	7個月～1年	1至5年	5年以上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流出	($2,397,401)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流入	2,390,147	-	-	-	-
	($ 7,254)	$ -	$ -	$ -	$ -

109年12月31日

	0～3個月	4～6個月	7個月～1年	1至5年	5年以上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流出	($ 633,522)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流入	640,320	-	-	-	-
	$ 6,798	$ -	$ -	$ -	$ -

109 年 9 月 30 日

	0～3 個 月	4～6 個 月	7個月～1年	1 至 5 年	5 年 以 上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流　出	($ 910,104)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流　入	909,151	-	-	-	-
	($ 953)	$ -	$ -	$ -	$ -

(3) 融資額度

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
無擔保金融業及非金融業透支額度			
一已動用金額	$ 100,000	$ 175,000	$ 250,000
一未動用金額	1,000,000	2,000,000	1,700,000
	$ 1,100,000	$ 2,175,000	$ 1,950,000
有擔保金融業及非金融業透支額度			
一已動用金額	$23,011,595	$23,637,001	$24,906,630
一未動用金額	11,534,200	29,847,000	568,000
	$34,545,795	$53,484,001	$25,474,630

二七、關係人交易

本公司及子公司（係本公司之關係人）間之交易、帳戶餘額、收益及費損於合併時全數予以銷除，故未揭露於本附註。除已於其他附註揭露外，本公司與其他關係人間之交易如下。

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
黃崇仁	主要管理階層
邵章榮	主要管理階層
林盈禎	主要管理階層
吳明長	主要管理階層
徐震球	主要管理階層（109 年 4 月 10 日退休後為非關係人）
陳瑞隆	主要管理階層(109 年 8 月辭任後為非關係人)
台灣光罩股份有限公司	實質關係人（109 年 9 月 24 日後為非關係人）
智立投資股份有限公司	實質關係人
智豐科技股份有限公司	實質關係人
黃毓秀	實質關係人

（接次頁）

（承前頁）

關係人名稱	與本公司之關係
Zentel Japan Corporation	實質關係人
Powerchip Corporation Japan	實質關係人
智仁科技開發股份有限公司	實質關係人（109 年 9 月 24 日前為關聯企業）
世成科技股份有限公司	實質關係人（109 年 9 月 24 日前為關聯企業）
智成電子股份有限公司	實質關係人（109 年 9 月 24 日前為關聯企業）
宏麗數位創意股份有限公司	實質關係人

(二) 營業收入

	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
實質關係人	$ 949,074	$ 623,190	$ 2,958,234	$ 1,639,406

(三) 取得之不動產、廠房及設備

	取得價款			
	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
實質關係人	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000

(四) 銷貨成本－權利金

	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
實質關係人	$ 3,586	$ 386	$ 11,280	$ 386
關聯企業	-	4,472	-	14,846
	$ 3,586	$ 4,858	$ 11,280	$ 15,232

(五) 製造費用

	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
實質關係人	$ -	$ 20	$ 6,359	$ 3,958

(六) 推銷費用

	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
實質關係人	$ -	$ -	$ 157	$ 86

(七) 管理費用

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
實質關係人	$ 1,308	$ 7,936	$ 5,179	$ 10,551
關聯企業	-	229	-	469
	$ 1,308	$ 8,165	$ 5,179	$ 11,020

(八) 研發費用

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
實質關係人	$ 1,000	$ -	$ 8,385	$ 789
關聯企業	-	5,888	-	17,885
	$ 1,000	$ 5,888	$ 8,385	$ 18,674

(九) 其他收益及費損淨額

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
主要管理階層	$ 6	$ 19	$ 18	$ 20
實質關係人	1,935	2,011	6,713	6,338
母 公 司	-	1	-	1
	$ 1,941	$ 2,031	$ 6,731	$ 6,359

(十) 應收帳款

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
實質關係人	$ 307,058	$ 253,494	$ 217,040

(十一) 向關係人借款（帳列長期借款含一年內到期之長期借款）:

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
實質關係人	$ -	$ 735,000	$ 735,000

財務成本

	110年7月1日 至9月30日	109年7月1日 至9月30日	110年1月1日 至9月30日	109年1月1日 至9月30日
實質關係人	$ 507	$ 3,335	$ 7,068	$ 6,198

本公司向關係人借款之借款利率於 109 年 12 月 31 日及 109 年 9 月 30 日為 1.80%。上列借款為擔保借款。

(十二) 合約負債

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
實質關係人	$ -	$ 20,391	$ 41,660

(十三) 其他應付款

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
實質關係人	$ 3,585	$ 12,502	$ 123,654

(十四) 存出保證金

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
主要管理階層	$ 1	$ 1	$ 1
實質關係人	1	1	1
	$ 2	$ 2	$ 2

本公司與關係人間晶圓代工之銷貨價格，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司支付關係人之權利金，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人間之取得之不動產、廠房及設備，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人之製造費用、推銷費用、管理費用及研發費用係依雙方議定之合作協議，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人間之其他收益及費損，係依據雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

流通在外之應收關係人款項未收取保證金或任何擔保品。

本公司合約負債之銷貨條件，係與客戶交易時參考市場行情、議定價格及數量。

上述之其他應付關係人款項主要係技術開發、權利金費用及利息費用產生。

除上述交易外，本公司與其他關係人間之交易，係按一般交易條件及價格辦理。

(十五) 承租協議

關係人類別／名稱	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
取得使用權資產				
實質關係人	$ 2,500	$ -	$ 2,500	$ -

帳列項目	關係人類別／名稱	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
租賃負債－流動	主要管理階層	$ 82	$ 81	$ 80
	實質關係人	14,100	13,714	14,295
		$ 14,182	$ 13,795	$ 14,375
租賃負債－非流動	主要管理階層	$ 97	$ 165	$ 178
	實質關係人	15,154	24,831	27,860
		$ 15,251	$ 24,996	$ 28,038

帳列項目	關係人類別／名稱	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
財務成本	主要管理階層	$ 1	$ -	$ 3	$ 4
	實質關係人	126	17	410	62
	關聯企業	-	165	-	558
		$ 127	$ 182	$ 413	$ 624

本公司向關係人承租辦公室、停車位及公務車，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金定期支付。

(十六) 對主要管理階層之薪酬

110 年及 109 年 7 月 1 日至 9 月 30 日與 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日對董事及其他主要管理階層之薪酬總額如下：

	110年7月1日至9月30日	109年7月1日至9月30日	110年1月1日至9月30日	109年1月1日至9月30日
短期員工福利	$ 235,034	$ 75,220	$ 687,159	$ 193,951
退職後福利	-	-	24,753	38,227
股份基礎給付	14,963	-	78,626	-
	$ 249,997	$ 75,220	$ 790,538	$ 232,178

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、質抵押之資產

本公司下列資產已提供作為長期借款、天然氣使用、承租科管局土地及保稅品出區之擔保品：

	110年9月30日	109年12月31日	109年9月30日
不動產、廠房及設備	$ 29,443,098	$ 34,146,212	$ 26,207,443
受限制存款（帳列其他金融資產）	1,707,931	1,892,931	1,915,931
	$ 31,151,029	$ 36,039,143	$ 28,123,374

二九、重大或有負債及未認列之合約承諾

除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

(一) 力積電公司分別於 92 年 8 月、94 年 3 月、97 年 6 月、99 年 3 月、10 月、100 年 7 月及 102 年 7 月與 Micron Memory Japan, Inc.（原 Elpida Memory Inc.）簽署若干動態隨機存取記憶體技術移轉與授權合約，力積電公司承諾自技術移轉完成後 5 年內支付一定金額之技術授權費及依約定產品之售價給付一定比例之權利金。惟雙方另於 100 年 5 月及 102 年 7 月簽署合作協議，修訂權利金支付比例。

(二) 力積電公司分別於 92 年 8 月及 94 年 3 月與某公司簽署若干動態隨機存取記憶體技術之專利授權合約，力積電公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(三) 力積電公司於 92 年 8 月與某公司等簽署若干動態隨機存取記憶體之專利技術授權合約，力積電公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(四) 力積電公司於 108 年 7 月與愛爾蘭商遠東金士頓公司簽訂代工合約至 110 年 10 月 31 日止，力積電公司承諾以約定價格為其製造記憶體產品。

(五) 力積電公司與數家供應商簽訂長期原物料進貨合約，以確保原物料穩定供貨，其中約定本公司須購買之相關最低數量及價格。

(六) 力積電公司與部分客戶簽訂合約，於客戶提供保證金或其他擔保品後，力積電公司依合約約定期限提供特定產能予該客戶。

(七) 力積電公司刻正興建新廠，簽訂之工程建造合約總價 10,163,906 仟元，截至 110 年 9 月 30 日止尚未認列金額為 9,380,524 仟元。

三十、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本公司各個體功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債資訊如下：

110 年 9 月 30 日

	外幣	匯率	帳面價值
外幣資產			
貨幣性項目			
美金	$ 547,227	27.853	$ 15,241,920
歐元	551	32.32	17,815
日幣	1,729,094	0.2490	430,544
人民幣	3,106	4.31	13,388
外幣負債			
貨幣性項目			
美金	388,794	27.853	10,829,089
歐元	11,340	32.32	366,502
日幣	2,120,977	0.2490	528,123

109 年 12 月 31 日

	外幣	匯率	帳面價值
外幣資產			
貨幣性項目			
美金	$ 361,840	28.372	$ 10,266,114
歐元	229	34.89	7,990
日幣	872,640	0.2751	240,063
人民幣	3,059	4.34	13,275
外幣負債			
貨幣性項目			
美金	270,993	28.372	7,688,620
歐元	11,565	34.89	403,504
日幣	2,478,059	0.2751	681,714

109 年 9 月 30 日

	外幣	匯率	帳面價值
外幣資產			
貨幣性項目			
美金	$ 333,316	29.05	$ 9,682,832
歐元	35	34.08	1,185
日幣	2,032,076	0.2752	559,227
人民幣	3,042	4.27	12,989
外幣負債			
貨幣性項目			
美金	232,424	29.05	6,751,913
歐元	11,449	34.08	390,166
日幣	4,666,330	0.2752	1,284,174

本公司主要承擔美金及新台幣之外幣匯率風險。以下資訊係按持有外幣個體之功能性貨幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等功能性貨幣換算至表達貨幣之匯率。具重大影響之外幣兌換損益（已實現及未實現）如下：

	110年7月1日至9月30日		109年7月1日至9月30日	
功能性貨幣	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益
新台幣	1(新台幣：新台幣)	$ 72	1(新台幣：新台幣)	($ 121,395)

	110年1月1日至9月30日		109年1月1日至9月30日	
功能性貨幣	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益
新台幣	1(新台幣：新台幣)	($ 191,342)	1(新台幣：新台幣)	($ 140,716)

三一、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊：

1. 資金貸與他人。(無)
2. 為他人背書保證。(無)
3. 期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)。(無)

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上。

5. 取得不動產之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上。(附表一)

6. 處分不動產之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上。(無)

7. 與關係人進、銷貨之金額達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。(附表二)

8. 應收關係人款項達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。(附表三)

9. 從事衍生工具交易。(本公司從事衍生性商品相關資訊請參閱附註七及二六)

10. 被投資公司資訊、所在地區…等相關資訊。(附表四)

11. 其他：母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額。(附表五)

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。(無)

2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益。(無)

(四) 主要股東資訊：股權比例達 5%以上之股東名稱、持股數額及比例。(附表六)

三二、<u>部門資訊</u>

力積電公司及子公司之營運決策者用以分配資源及評量部門績效係著重於產品銷售之財務資訊，而每一產品皆具有相類似之經濟特性，每一產品使用類似之製程以生產類似之產品，且透過統一集中之銷售方式銷售，故力積電公司及子公司彙總為單一營運部門報導。另力積電公司及子公司提供給營運決策者複核之部門資訊，其衡量基礎與財務報表相同，故 110 年及 109 年 7 月 1 日至 9 月 30 日與 110 年及 109 年 1 月 1 日至 9 月 30 日應報導之部門收入及營運結果可參照 110

年及109年7月1日至9月30日與110年及109年1月1日至9月30日之合併綜合損益表；110年9月30日暨109年12月31日及9月30日應報導之部門資產可參照110年9月30日暨109年12月31日及9月30日之合併資產負債表。

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

取得不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上

民國110年1月1日至9月30日

附表一

單位：新台幣仟元

取得不動產之公司	財產名稱	事實發生日	交易金額（註）	價款支付情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決定之參考依據	取得目的及使用情形	其他約定事項
							所有人	與發行人之關係	移轉日期	金額			
力積電公司	房屋及建築	110.1.12~110.9.10	$8,637,001	依工程進度驗收後月結付款	互助營造股份有限公司及東鋼鋼結構股份有限公司等共12家	無	不適用	不適用	不適用	不適用	比價及議價	營業使用	無

註：係簽訂之工程建造訂單總價。

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

與關係人進、銷貨交易金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上

民國 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

附表二

單位：新台幣仟元

進（銷）貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收（付）票據、帳款		備註
			進／銷貨	金額	佔總進／銷貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率	
力積電公司	智豐科技股份有限公司	實質關係人	銷貨	$ 2,606,746	6%	註 1	$ -	—	$ 286,012	3%	
	Zentel Japan Corporation	實質關係人	銷貨	323,603	1%	註 2	-	—	14,980	-	

註 1：主要係月結 60 天付款。

註 2：主要係貨到 30 天付款。

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

應收關係人款項達新臺幣1億元或實收資本額20%以上

民國110年9月30日

附表三

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
力積電公司	智豐科技股份有限公司	實質關係人	$ 286,012	15.89次	$ -	—	$ -	$ -

力晶積成電子製造股份有限公司及子公司

被投資公司資訊、所在地區...等相關資訊

民國 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

附表四

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數（仟股）	比率（%）	帳面金額			
力積電公司	Global Powertec Co., Ltd.	英屬維京群島	從事各式投資業務	$ 1	$ 1	-	100.00	($ 57,520)	$ 23,623	$ 23,623	—
Global Powertec Co., Ltd.	PowerMemory Inc.	日本	從事半導體及電子零組件之開發及販售	703,165	703,165	500	100.00	19,548	12,593	12,593	—
	Maxram Inc.	日本	從事半導體及電子零組件之開發及販售	22,415	22,415	800	100.00	21,236	15,155	15,155	—

力晶積成電子製造有限公司及子公司

母子公司間及各子公司業務關係及重要交易往來情形

民國 110 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

附表五

單位：新台幣仟元

交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係（註1）	交易往來情形			
			科目	金額	交易條件	佔合併總營收或總資產之比率
力積電公司	PowerMemory 公司	1	研發費用	$ 72,440	註 2	-
力積電公司	Maxram 公司	1	研發費用	88,475	註 2	-

註 1： 1 係代表母公司對子公司之交易。

註 2： 係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

力晶積成電子製造股份有限公司

主要股東資訊

民國 110 年 9 月 30 日

附表六

主要股東名稱	股份	
	持有股數（股）	持股比例
力晶科技股份有限公司	835,486,370	24.54%

註 1： 本表主要股東資訊係由集保公司以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5%以上資料。本公司合併財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2： 上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10%之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

【附件四】

一〇八年度個體財務報告及會計師查核報告

股票代碼：6770

力晶積成電子製造股份有限公司

個體財務報告暨會計師查核報告

民國 108 及 107 年度

地址：新竹科學工業園區新竹市力行一路18號

電話：(03)579-5000

§目　　錄§

項目	頁次	財務報告附註編號
一、封　　面	1	-
二、目　　錄	2	-
三、會計師查核報告	3～5	-
四、個體資產負債表	6	-
五、個體綜合損益表	7～8	-
六、個體權益變動表	9	-
七、個體現金流量表	10～11	-
八、個體財務報告附註		
(一) 公司沿革	12	一
(二) 通過財務報告之日期及程序	12	二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	12～16	三
(四) 重大會計政策之彙總說明	16～29	四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	29～30	五
(六) 重要會計項目之說明	30～62	六～二六
(七) 關係人交易	62～67	二七
(八) 質抵押之資產	67	二八
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	67～68	二九
(十) 其　　他	68～69	三十
(十一) 重大之災害損失	-	-
(十二) 重大之期後事項	-	-
(十三) 具重大影響之外幣資產及負債資訊	69	三一
(十四)附註揭露事項		
1. 重大交易事項相關資訊	70～72	三二
2. 轉投資事業相關資訊	70～72	三二
3. 大陸投資資訊	70	三二
(十五) 部門資訊	-	-
九、重要會計項目明細表	73～86	-

會計師查核報告

力晶積成電子製造股份有限公司　公鑒：

查核意見

力晶積成電子製造股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達力晶積成電子製造股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與力晶積成電子製造股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估力晶積成電子製造股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算力晶積成電子製造股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力晶積成電子製造股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對力晶積成電子製造股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使力晶積成電子製造股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基

礎。惟未來事件或情況可能導致力晶積成電子製造股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於力晶積成電子製造股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成力晶積成電子製造股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

強調事項

如財務報告附註一、十及三十所述，力晶積成電子製造股份有限公司於民國 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶科技股份有限公司全部或主要之相關營業，並由力晶積成電子製造股份有限公司發行新股予母公司力晶科技股份有限公司做為收購之對價，及由母公司力晶科技股份有限公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.讓與力晶積成電子製造股份有限公司；與民國 108 年 4 月 1 日由力晶積成電子製造股份有限公司將持股 100%之富碩投資股份有限公司及 Sprout International Limited 全數出售予母公司力晶科技股份有限公司。前述交易係屬共同控制下之組織重組，是以應追溯視為自始取得或除列，並重編比較期間之個體財務報告，是項重編使民國 107 年 12 月 31 日之共同控制下前手權益及後手權益分別調整新台幣 25,295,906 仟元及(197,512)仟元，民國 107 年度共同控制下前手權益及後手權益綜合損益總額分別調整新台幣 5,892,189 仟元及 12,032 仟元。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃裕峰　　會計師 鍾鳴遠

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中華民國 109 年 3 月 9 日

力晶積成電子製造股份有限公司

個體資產負債表

民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	108年12月31日 金額	%	107年12月31日（重編後並經查核） 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二六）	$ 3,977,560	5	$ 6,965,993	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二六）	4,372	-	7,151	-
1170	應收帳款－非關係人淨額（附註四、八及二六）	5,344,970	7	6,251,317	9
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、八、二六及二七）	49,914	-	129,542	-
1200	其他應收款（附註四、二六及二七）	453,449	1	569,873	1
130X	存貨（附註四、九及二七）	6,385,497	9	6,743,775	10
1410	預付款項（附註二九）	660,413	1	814,243	1
1476	其他金融資產－流動（附註四、六、二六及二八）	536,531	1	761,879	1
1479	其他流動資產－其他	192,217	-	33,117	-
11XX	流動資產總計	17,604,923	24	22,276,890	33
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、十四及二八）	47,358,384	65	40,687,127	60
1755	使用權資產（附註三、四、五、十二及二七）	4,393,945	6	-	-
1780	無形資產（附註四及十三）	241,728	-	526,924	1
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二二）	620,586	1	1,780,710	3
1915	預付設備款	1,540,275	2	1,245,100	2
1920	存出保證金（附註四、二六及二七）	7,077	-	32,010	-
1980	其他金融資產－非流動（附註四、六、二六及二八）	1,360,000	2	863,000	1
1990	其他非流動資產－其他（附註二九）	51,152	-	119,391	-
15XX	非流動資產總計	55,573,147	76	45,254,262	67
1XXX	資產總計	$ 73,178,070	100	$ 67,531,152	100

代碼	負債及權益	108年12月31日 金額	%	107年12月31日（重編後並經查核） 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十四、二六及二七）	$ -	-	$ 689,435	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及二六）	-	-	81	-
2130	合約負債－流動（附註四、二十及二七）	926,359	1	1,255,598	2
2170	應付帳款－非關係人（附註二六）	2,583,447	4	3,015,986	5
2213	應付設備款（附註二六）	1,797,230	2	2,206,140	3
2219	其他應付款（附註十五、二六及二七）	3,489,677	5	5,947,627	9
2230	本期所得稅負債（附註四及二二）	-	-	200,208	-
2250	負債準備－流動（附註四、十七及二六）	-	-	234,389	-
2280	租賃負債－流動（附註三、四、五、十二、二六及二七）	215,566	-	-	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十四、二六及二八）	5,512,049	8	4,580,670	7
2399	其他流動負債－其他（附註十六及二六）	1,078,872	1	437,907	1
21XX	流動負債總計	15,603,200	21	18,568,041	28
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十四、二六及二八）	21,163,213	29	15,435,055	23
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	620,586	1	1,760,110	3
2580	租賃負債－非流動（附註三、四、五、十二、二六及二七）	4,083,303	6	-	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）	1,444,727	2	1,454,058	2
2645	存入保證金（附註二六及二七）	329,221	-	311,120	-
2650	採用權益法之投資貸餘（附註四及十）	57,439	-	41,961	-
25XX	非流動負債總計	27,698,489	38	19,002,304	28
2XXX	負債總計	43,301,689	59	37,570,345	56
	屬於母公司業主之權益（附註四及十九）				
3110	普通股股本	31,051,965	43	3,586,674	5
3200	資本公積	181,927	-	89,200	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	238,155	-	139,562	-
3350	未分配盈餘	(1,595,372)	(2)	1,050,937	2
3300	保留盈餘總計	(1,357,217)	(2)	1,190,499	2
3400	其他權益	(294)	-	(3,960)	-
31XX	母公司業主之權益總計	29,876,381	41	4,862,413	7
35XX	共同控制下前手權益	-	-	25,295,906	37
35XX	共同控制下後手權益	-	-	(197,512)	-
3XXX	權益總計	29,876,381	41	29,960,807	44
	負債及權益總計	$ 73,178,070	100	$ 67,531,152	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：力晶科技股份有限公司　代表人：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司

個體損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股（虧損）盈餘為元

代碼		108年度 金額	108年度 %	107年度（重編後並經查核） 金額	107年度（重編後並經查核） %
4100	營業收入淨額（附註四、二十及二七）	$ 35,897,121	100	$ 49,913,779	100
5110	營業成本（附註四、九、二一及二七）	32,896,453	92	34,633,514	69
5900	營業毛利	3,000,668	8	15,280,265	31
	營業費用（附註二一及二七）				
6100	推銷費用	300,790	1	461,925	1
6200	管理費用	1,898,543	5	2,646,378	5
6300	研究發展費用	3,061,315	9	3,548,820	7
6000	營業費用合計	5,260,648	15	6,657,123	13
6500	其他收益及費損淨額（附註二一及二七）	172,015	1	256,948	-
6900	營業淨（損）利	(2,087,965)	(6)	8,880,090	18
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	62,531	-	92,553	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	(64,025)	-	113,755	-
7050	財務成本（附註四、十四、二一及二七）	(513,094)	(2)	(455,427)	(1)
7060	採用權益法認列之子公司損益份額（附註四及十）	(15,184)	-	5,658	-
7000	營業外收入及支出合計	(529,772)	(2)	(243,461)	(1)
7900	稅前淨（損）利	(2,617,737)	(8)	8,636,629	17
7950	所得稅費用（附註三、四、五及二二）	(25,447)	-	(1,721,885)	(3)
8200	本年度淨（損）利	(2,643,184)	(8)	6,914,744	14

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108年度 金　額	108年度 %	107年度（重編後並經查核） 金　額	107年度（重編後並經查核） %
	其他綜合損益（附註四、十八及十九）				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	($ 110,925)	-	($ 15,281)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	-	-	2,892	-
	後續可能重分類至損益之項目：				
8380	採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額	(294)	-	346	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(111,219)	-	(12,043)	-
8500	本年度綜合損益總額	($ 2,754,403)	(8)	$ 6,902,701	14
	淨（損）利歸屬於：				
8610	母公司業主	($ 1,480,370)	(4)	$ 985,928	2
8615	共同控制下前手權益	(1,162,814)	(3)	5,890,576	12
8615	共同控制下後手權益	-	-	38,240	-
8600		($ 2,643,184)	(7)	$ 6,914,744	14
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	($ 1,551,814)	(5)	$ 998,480	2
8715	共同控制下前手權益	(1,162,814)	(3)	5,892,189	12
8715	共同控制下後手權益	(39,775)	-	12,032	-
8700		($ 2,754,403)	(8)	$ 6,902,701	14
	每股（虧損）盈餘（附註二三）				
9710	基　本	($ 0.94)		$ 2.56	
9810	稀　釋	($ 0.94)		$ 2.54	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：[illegible]公司　代表人：[illegible]　經理人：謝[illegible]　會計主管：邱垂源

[illegible]公司

民國[illegible]年1月1日至12月31日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼		歸屬於母公司業主之權益（附註十九）											
							其他權益項目						
		股本			保留盈餘			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	備供出售金融資產未實現損益				
		股數（仟股）	金額	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			總計	共同控制下前手權益	共同控制下後手權益	權益總計
A1	107年1月1日餘額	306,364	$ 3,063,642	$ 89,200	$ 81,447	$ 581,147	($ 4,127)	$ -	$ 53,136	$ 3,864,445	$ -	$ -	$ 3,864,445
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	140,819	-	(70,724)	(53,136)	16,959	-	(11,223)	5,736
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手及後手權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,554,406	(215,792)	25,338,614
A5	107年1月1日重編後餘額	306,364	3,063,642	89,200	81,447	721,966	(4,127)	(70,724)	-	3,881,404	25,554,406	(227,015)	29,208,795
	106年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	58,115	(58,115)	-	-	-	-	-	-	-
B9	本公司股東股票股利	52,303	523,032	-	-	(523,032)	-	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法之投資權益變動	-	-	-	-	(543)	-	-	-	(543)	-	543	-
D1	107年度淨利	-	-	-	-	985,928	-	-	-	985,928	5,890,576	38,240	6,914,744
D3	107年度其他綜合損益	-	-	-	-	(16,548)	(189)	29,289	-	12,552	1,613	(26,208)	(12,043)
D5	107年度綜合損益總額	-	-	-	-	969,380	(189)	29,289	-	998,480	5,892,189	12,032	6,902,701
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(16,928)	-	-	-	(16,928)	-	16,928	-
T1	前手權益於本年度分配員工酬勞轉列股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,380	-	286,380
T1	前手權益於本年度分配現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,908,694)	-	(3,908,694)
T1	歸屬於前手權益之投資合資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,528,375)	-	(2,528,375)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(41,791)	-	41,791	-	-	-	-	-
Z1	107年12月31日餘額	358,667	3,586,674	89,200	139,562	1,050,937	(4,316)	356	-	4,862,413	25,295,906	(197,512)	29,960,807
	107年度盈餘指撥及分配												
B1	法定盈餘公積	-	-	-	98,593	(98,593)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(95,234)	-	-	-	(95,234)	-	-	(95,234)
B9	本公司股東股票股利	85,711	857,109	-	-	(857,109)	-	-	-	-	-	-	-
D1	108年度淨損	-	-	-	-	(1,480,370)	-	-	-	(1,480,370)	(1,162,814)	-	(2,643,184)
D3	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	(110,925)	(294)	39,775	-	(71,444)	-	(39,775)	(111,219)
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	(1,591,295)	(294)	39,775	-	(1,551,814)	(1,162,814)	(39,775)	(2,754,403)
N1	股份基礎給付交易	-	-	11,247	-	-	-	-	-	11,247	-	-	11,247
E1	現金增資	400,000	4,000,000	40,000	-	-	-	-	-	4,040,000	-	-	4,040,000
H3	組織重組	2,260,818	22,608,182	41,480	-	(4,078)	4,316	(40,131)	-	22,609,769	(24,593,842)	237,287	(1,746,786)
T1	前手權益於本年度分配員工酬勞轉列股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,750	-	460,750
Z1	108年12月31日餘額	[illegible]	[illegible]	$ 181,927	$ 238,155	($ 1,595,372)	($ 294)	$ -	$ -	$ 29,876,381	$ -	$ -	$ 29,876,381

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：力晶科技股份有限公司　代表人：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱重源

力晶積成電子製造股份有限公司

[illegible]

民國 108 年及 [illegible] 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		108 年度	107 年度（重編後並經查核）
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨（損）利	($ 2,617,737)	$ 8,636,629
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,847,723	3,926,369
A20200	攤銷費用	331,790	332,184
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失（利益）	2,698	(2,529)
A20900	財務成本	513,094	455,427
A21200	利息收入	(62,531)	(91,943)
A21300	股利收入	-	(610)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	11,247	-
A22300	採用權益法認列之子公司損失（利益）之份額	15,184	(5,658)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(950)	(15,983)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	350,932	439,322
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(70,406)	42,746
A29900	負債準備提列數	-	34,389
A29900	退款負債提列（迴轉）數	31,723	(69,493)
A29900	押金設算利息收入	54	7
A29900	押金設算利息費用	(1)	(6)
A29900	其　他	(1,401)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款（含關係人）	899,396	(1,098,866)
A31180	其他應收款（含關係人）	36,444	(233,291)
A31200	存　貨	7,346	(1,079,556)
A31230	預付款項	44,225	3,452
A31240	其他流動資產	(160,097)	(32,735)
A32125	合約負債	(140,971)	766,041
A32150	應付帳款	(432,539)	210,477
A32180	其他應付款（含關係人）	(1,850,908)	1,145,245
A32240	淨確定福利負債－非流動	(120,256)	(120,385)
A32230	其他流動負債	422,394	58,004
A33000	營運產生之淨現金流入	2,056,453	13,299,237
A33100	收取之利息	59,780	90,968
A33500	支付之所得稅	(36,266)	(434,729)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,079,967	12,955,476

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		108 年度	107 年度（重編後並經查核）
	投資活動之現金流量		
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之投資	$ -	$ 17,761
B02700	取得不動產、廠房及設備	(12,166,035)	(10,425,048)
B02800	處分不動產、廠房及設備	56,666	17,837
B03700	存出保證金增加	(198)	(62)
B03800	存出保證金減少	873	175
B04500	取得無形資產	(35,232)	(16,817)
B06500	其他金融資產增加	(492,139)	(860,598)
B07600	收取股利	-	610
BBBB	投資活動之淨現金流出	(12,636,065)	(11,266,142)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,250,000	1,819,435
C00200	短期借款減少	(2,939,435)	(3,119,435)
C01600	舉借長期借款	12,277,800	32,231,771
C01700	償還長期借款	(5,676,344)	(17,662,076)
C03000	存入保證金增加	210,311	268,104
C03100	存入保證金減少	(72,983)	(140,494)
C04000	應付租賃款減少	-	(3,218,567)
C04020	租賃負債本金償還	(98,666)	-
C04500	發放現金股利	(95,234)	(3,908,694)
C04600	現金增資	4,040,000	-
C05600	支付之利息	(407,151)	(457,402)
C09900	其他預付款項	-	(93,000)
C09900	共同控制下前手權益減少數	(1,920,633)	(2,528,375)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	7,567,665	3,191,267
EEEE	現金及約當現金淨（減少）增加數	(2,988,433)	4,880,601
E00100	年初現金及約當現金餘額	6,965,993	2,085,392
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 3,977,560	$ 6,965,993

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：力晶科技股份有限公司　代表人：黃崇仁　經理人：謝再居　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司

個體財務報表附註

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（除另註明外，金額以新台幣仟元為單位）

一、公司沿革

力晶積成電子製造股份有限公司（以下稱「本公司」），係由力晶科技股份有限公司（以下稱「力晶公司」）分割設立，以 97 年 4 月 1 日為分割基準日，並經科學工業園區管理局核准設立。主要營業項目為從事各式積體電路之研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工及銷售。

力晶公司為重整集團組織架構，進行以下組織重整，其交易因屬共同控制下之組織重組，應視為自始即已合併而追溯重編前期比較財務報表：

(一) 本公司於 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業，並由本公司發行新股予力晶公司作為收購之對價；及由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.（以下稱「Global Powertec 公司」）讓與本公司；

(二) 108 年 4 月 1 日由本公司將持股 100%之富碩投資股份有限公司（以下稱「富碩公司」）及 Sprout International Limited（以下稱「Sprout 公司」）全數出售予力晶公司。

本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告於 109 年 3 月 9 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

除下列說明外，適用修正後之證券發行人財務報告編製準則及金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動：

1. 國際財務報導準則第 16 號「租賃」

國際財務報導準則第 16 號規範租賃協議之辨認與出租人及承租人會計處理，該準則將取代國際會計準則第 17 號「租賃」及國際財務報導解釋第 4 號「決定一項安排是否包含租賃」等相關解釋。相關會計政策請參閱附註四。

<u>租賃定義</u>

本公司選擇僅就 108 年 1 月 1 日以後簽訂（或變動）之合約依國際財務報導準則第 16 號評估是否係屬（或包含）租賃，先前已依國際會計準則第 17 號及國際財務報導解釋第 4 號辨認為租賃之合約不予重新評估並依國際財務報導準則第 16 號之過渡規定處理。

<u>本公司為承租人</u>

除低價值標的資產租賃及短期租賃選擇按直線基礎認列費用外，其他租賃係於個體資產負債表認列使用權資產及租賃負債。個體綜合損益表係分別表達使用權資產之折舊費用及租賃負債按有效利息法所產生之利息費用且於個體現金流量表將償付租賃負債之本金金額及支付利息部分皆表達為籌資活動。適用國際財務報導準則第 16 號前，分類為營業租賃之合約係按直線基礎認列費用。營業租賃現金流量於個體現金流量表係表達於營業活動。分類為融資租賃之合約係於個體資產負債表認列租賃資產及應付租賃款。

本公司選擇將追溯適用國際財務報導準則第 16 號之累積影響數調整於首次適用日，不重編比較資訊。

先前依國際會計準則第 17 號以營業租賃處理之協議，除短期租賃外，其他租賃於 108 年 1 月 1 日租賃負債之衡量係以剩餘租賃給付按該日承租人之增額借款利率折現，使用權資產係以該日之租賃負債金額並調整先前已認列之預付或應付租賃給付金額衡量。所認列之使用權資產均適用國際會計準則第 36 號評估減損。

本公司對 108 年 1 月 1 日使用權資產亦適用下列權宜作法：

(1) 對具有合理類似特性之租賃組合使用單一折現率衡量租賃負債。

(2) 租賃期間於 108 年 12 月 31 日以前結束之租賃依短期租賃處理。

(3) 不將原始直接成本計入 108 年 1 月 1 日之使用權資產衡量中。

(4) 進行租賃負債之衡量時，對諸如租賃期間之決定依 108 年 1 月 1 日之預計使用情形。

本公司於 108 年 1 月 1 日認列租賃負債所適用之增額借款利率加權平均數為 2.85%，該租賃負債金額與 107 年 12 月 31 日不可取消營業租賃之未來最低租賃給付總額之差異說明如下：

107 年 12 月 31 日不可取消營業租賃之未來最低租賃給付總額	$1,597,354
減：適用豁免之短期租賃	(4,588)
108 年 1 月 1 日未折現總額	$1,592,766
按 108 年 1 月 1 日增額借款利率折現後之現值	$1,292,489
加：因延長租賃使用權產生之調整	534,793
108 年 1 月 1 日租賃負債餘額	$1,827,282

本公司為出租人

於過渡時對出租人之租賃不作任何調整，且自 108 年 1 月 1 日起始適用國際財務報導準則第 16 號。

首次適用國際財務報導準則第 16 號對 108 年 1 月 1 日各資產、負債及權益項目調整如下：

	108年1月1日重編前金額	首次適用之調整	108年1月1日重編後金額
使用權資產	$ -	$ 1,827,282	$ 1,827,282
資產影響	$ -	$ 1,827,282	$ 1,827,282
租賃負債－流動	$ -	$ 94,723	$ 94,723
租賃負債－非流動	-	1,732,559	1,732,559
負債影響	$ -	$ 1,827,282	$ 1,827,282

2. 國際財務報導解釋第 23 號「所得稅務處理之不確定性」

國際財務報導解釋第 23 號釐清當存有所得稅務處理之不確定性時，本公司須假設稅務機關將可取具所有相關資料進行審查，若判斷其申報之稅務處理很有可能被稅務機關接受，本公司對於課稅所得、課稅基礎、未使用課稅損失、未使用課稅抵減及稅率之決定必須與申報所得稅時所採用之稅務處理一致。若稅務機關並非很有可能接受申報之稅務處理，本公司須採最可能金額或預期值（應採兩者中較能預測不確定性最終結果之方法）評估。若事實及情況改變，本公司須重評估其判斷與估計。

(二) 109 年適用之金管會認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會（IASB）發布之生效日
國際財務報導準則第 3 號之修正「業務之定義」	2020 年 1 月 1 日（註 1）
國際財務報導準則第 9 號、國際會計準則第 39 號及國際財務報導準則第 7 號之修正「利率指標變革」	2020 年 1 月 1 日（註 2）
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「重大性之定義」	2020 年 1 月 1 日（註 3）

註 1： 收購日在年度報導期間開始於 2020 年 1 月 1 日以後之企業合併及於前述日期以後發生之資產取得適用此項修正。

註 2： 2020 年 1 月 1 日以後開始之年度期間追溯適用此項修正。

註 3： 2020 年 1 月 1 日以後開始之年度期間推延適用此項修正。

截至本個體財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註1)
國際財務報導準則第 10 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未　定
國際財務報導準則第 17 號「保險合約」	2021 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「將負債分類為流動或非流動」	2022 年 1 月 1 日

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

截至本個體財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本個體財務報告係依歷史成本基礎編製。歷史成本通常依照取得資產所支付對價之公允價值決定。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

本公司於編製個體財務報告時，對投資子公司採權益法處理。為使本個體財務報告之本年度損益、其他綜合損益及權益與本公司合併財務報告中歸屬於本公司業主之本年度損益、其他綜合損益及權益相同，個體基礎與合併基礎下若干會計處理差異係調整「採用權益法之投資」、「採用權益法之投資貸餘」、「採用權益法認列之子公司損益份額」、「採用權益法認列之子公司其他綜合損益份額」暨相關權益項目。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及
3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾 12 個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後 12 個月內到期清償之負債（即使於資產負債表日後至通過發布財務報告前已完成長期性之再融資或重新安排付款協議，亦屬流動負債），以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少 12 個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外　　幣

本公司編製個體財務報告時，以本公司功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。除為規避部分匯率風險而進行避險交易所產生之兌換差額外，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製個體財務報告時，本公司國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額列於其他綜合損益。

若本公司處分國外營運機構之所有權益，或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制，或處分國外營運機構之聯合協議或關聯企業後之保留權益係金融資產並按金融工具之會計政策處理，所有與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制，係按比例將累計兌換差額併入權益交易計算，但不認列為損益。在其他任何部分處分 國外營運機構之情況下，累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

(五) 存　　貨

存貨包括原料、在製品及製成品，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。另固定製造費用應按生產設備之正常產能分攤，因產能較低或設備閒置導致之未分攤固定製造費用，應於發生當年度認列銷貨成本。

本公司之存貨平時按標準成本計價，結帳日再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。

(六) 投資子公司

本公司採用權益法處理對子公司之投資。

子公司係指本公司具有控制之個體。

權益法下，投資原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益。

當本公司對子公司之損失份額等於或超過其在該子公司之權益（包括權益法下子公司之帳面金額及實質上屬於本公司對該子公司淨投資組成部分之其他長期權益）時，係繼續按持股比例認列損失。

取得成本超過本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；本公司於取得日所享有子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當期收益。

本公司評估減損時，係以財務報告整體考量現金產生單位並比較其可回收金額與帳面金額。嗣後若資產可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟資產於減損損失迴轉後之帳面金額，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列攤銷後之帳面金額。歸屬於商譽之減損損失不得於後續期間迴轉。

當喪失對子公司控制時，本公司係按喪失控制日之公允價值衡量其對前子公司之剩餘投資，剩餘投資之公允價值及任何處分價款與喪失控制當日之投資帳面金額之差額，列入當期損益。此外，於其他綜合損益中所認列與該子公司有關之所有金額，其會計處理係與本公司直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於個體財務報告予以銷除。本公司與子公司之逆流及側流交易所產生之損益，僅在與本公司對子公司權益無關之範圍內，認列於個體財務報告。

(七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損損失後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(八) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，並且於每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視。並推延適用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除　　列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(九) 有形、無形資產及合約成本相關資產之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示有形及無形資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至個別現金產生單位。

針對非確定耐用年限及尚未可供使用之無形資產，至少每年及有減損跡象時進行減損測試。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資

產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

適用國際財務報導準則第 15 號之客戶合約，因客戶合約所認列之存貨、不動產、廠房及設備及無形資產先依存貨減損規定及上述規定認列減損，次依合約成本相關資產之帳面金額超過提供相關商品或勞務預期可收取之對價剩餘金額扣除直接相關成本後之金額認列為減損損失，續將合約成本相關資產之帳面金額計入所屬現金產生單位，以進行現金產生單位之減損評估。

當減損損失於後續迴轉時，該資產、現金產生單位或合約成本相關資產之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產、現金產生單位或合約成本相關資產若未於以前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於個體資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

金融資產係分為透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資及按攤銷後成本衡量之金融資產。

A.透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產係強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。其產生之利益或損失係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

B.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

本公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，其後續公允價值變動認列於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於本公司具收款之權利時認列於損益，除非該收款之權利明顯代表部分投資成本之回收。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

C.按攤銷後成本衡量

現金及約當現金、債務工具投資、應收帳款（含關係人）、其他應收款項、受限制存款及存出保證金係按攤銷後成本衡量。

債務工具投資之合約條款為完全支付本金及流通在外本金金額之利息，且持有目的係以收取合約現金流量，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

按攤銷後成本衡量之各類金融資產於原始認列後，係以有效利息法決定之帳面價值減除任何減損損失之攤銷後成本衡量。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產及合約資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）。

應收帳款按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

於一按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。於一透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

2. 權益工具

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

3. 金融負債

(1) 後續衡量

除透過損益按公允價值衡量之金融負債外，所有金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量：

透過損益按公允價值衡量之金融負債

透過損益按公允價值衡量之金融負債包含持有供交易之金融負債。

持有供交易之金融負債係按公允價值衡量，其再衡量產生之利益或損失（包含該金融負債所支付之任何股利或利息）係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

4. 衍生工具

本公司簽訂之衍生工具包括遠期外匯合約，用以管理本公司之匯率風險。

衍生工具於簽訂衍生工具合約時，原始以公允價值認列，後續於資產負債表日按公允價值再衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

(十一) 負債準備

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為資產負債表日清償義務所需支出之最佳估計。負債準備係以清償義務之估計現金流量折現值衡量。

(十二) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，並於滿足各履約義務時認列收入。

商品銷貨收入

商品銷貨收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。本公司基於歷史經驗及考量不同之合約條件，以估計可能發生之銷貨退回及折讓，據以認列退款負債。

商品銷貨收入來自矽晶圓產品之銷售。產品於出貨時或運抵客戶指定地點時認列收入及應收帳款。銷售之預收款項，於商品認列收入前係認列為合約負債。

(十三) 租　　賃

108 年

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 本公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

本公司於轉租使用權資產時，係以使用權資產（而非標的資產）判斷轉租之分類。惟若主租賃係本公司適用認列豁免之短期租賃時，該轉租分類為營業租賃。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。因取得營業租賃所發生之原始直接成本，係加計至標的資產之帳面金額，並按直線基礎於租賃期間內認列為費用。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為收益。

2. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於個體資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。若租賃期間屆滿時將取得標的資產所有權，或若使用權資產之成本反映購買選擇權之行使，則自租賃開始日起至標的資產耐用年限屆滿時提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。租賃負債係單獨表達於個體資產負債表。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為費用。

<u>107 年</u>

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

1. 本公司為出租人

營業租賃之租賃收益係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。因協商與安排營業租賃所產生之原始直接成本，係加計至出租資產之帳面金額，並按直線基礎於租賃期間內認列為費用。營業租賃下，或有租金於發生當期認列為收益。

2. 本公司為承租人

融資租賃係以各期最低租賃給付現值總額或租賃開始日租賃資產公允價值較低者作為成本入帳，並同時認列應付租賃款負債。

每期所支付租賃款之隱含利息列為當期財務費用，若可直接歸屬於符合要件之資產者，則予以資本化。

營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用。

營業租賃所取得之租賃誘因係認列為負債。誘因利益總額按直線基礎認列為租金費用之減項。

租賃協議之或有租金於發生當認列為費用。

(十四) 借款成本

直接可歸屬於取得及建造符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，所有其他借款成本係於發生當期認列為損益。

(十五) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務之期間，將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服務成本及前期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時、計畫修正或縮減時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益、資產上限影響數之變動及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債係確定福利退休計畫之提撥短絀。

(十六) 股份基礎給付協議

給與員工之員工認股權

員工認股權係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。本公司辦理現金增資保留員工認購，係確認員工認購股數之日為給與日。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積。

(十七) 所得稅

所得稅費用係當期應付所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依我國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司、關聯企業及合資權益相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資及權益有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能有足夠課稅所得用以實現暫時性差異之利益，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、<u>重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源</u>

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

管理階層將對估計與基本假設持續檢視。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

重大會計判斷

(一) 租賃期間（適用於 108 年）

決定所承租資產之租賃期間時，本公司考量將產生經濟誘因以行使（或不行使）選擇權之所有攸關事實及情況，包括自租賃開始日至選擇權行使日間所有事實及情況之預期變動。考量主要因素包括選擇權所涵蓋期間之合約條款及條件、於合約期間進行之重大租賃權益改良及標的資產對承租人營運之重要性等。於本公司控制範圍內重大事項或情況重大改變發生時，重評估租賃期間。

估計及假設不確定性之主要來源

(一) 所得稅

遞延所得稅資產係於未來很有可能有足夠之課稅所得供可減除暫時性差異使用時方予以認列。評估遞延所得稅資產之可實現性時，必須涉及管理階層之重大會計判斷及估計，包含預期未來銷貨收入成長及利潤率、可使用之所得稅抵減及稅務規畫等假設。任何關於全球經濟環境、產業環境的變遷及法令的改變，均可能引起遞延所得稅資產之重大調整。

(二) 承租人增額借款利率（適用於 108 年）

決定租賃給付折現所使用之承租人增額借款利率，係以相當存續期間及幣別之無風險利率做為參考利率，並將所估計之承租人信用風險貼水及租賃特定調整（例如，資產特性及附有擔保等因素）納入考量。

六、現金及約當現金

	108年12月31日	107年12月31日
活期存款	$ 1,850,085	$ 2,947,615
支票存款	15,780	69,055
庫存現金	-	100
約當現金		
銀行定期存款	3,708,226	4,564,102
附買回債券	300,000	1,010,000
	5,874,091	8,590,872
受限制存款（帳列其他金融資產）	(1,896,531)	(1,624,879)
	$ 3,977,560	$ 6,965,993

銀行存款及附買回債券於資產負債表日之市場利率區間如下：

	108年12月31日	107年12月31日
銀行存款	0%~2.60%	0%~3.85%
附買回債券	0.53%	0.47%~0.53%

七、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債

	108年12月31日	107年12月31日
金融資產－流動		
強制透過損益按公允價值衡量		
衍生工具		
－遠期外匯合約	$ 4,372	$ 7,151
金融負債－流動		
持有供交易		
衍生工具		
－遠期外匯合約	$ -	$ 81

於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下：

	幣別	到期期間	合約金額（仟元）
108年12月31日			
賣出遠期外匯	美金兌新台幣	109.01.03	USD 5,000/ NTD 152,300
	美金兌日圓	109.01.06~109.01.30	USD 13,736/ JPY 1,500,000
107年12月31日			
賣出遠期外匯	美金兌新台幣	108.01.03~108.02.12	USD 51,000/ NTD 1,568,650
	美金兌日圓	108.01.08~108.02.14	USD 11,697/ JPY 1,300,000

本公司從事遠期外匯交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。

八、應收帳款

	108年12月31日	107年12月31日
按攤銷後成本衡量		
應收帳款－非關係人	$ 5,344,970	$ 6,251,317
減：備抵損失	-	-
	5,344,970	6,251,317
應收帳款－關係人	49,914	129,542
減：備抵損失	-	-
	49,914	129,542
應收帳款淨額	$ 5,394,884	$ 6,380,859

本公司對商品銷售之平均授信期間為月結 30～60 天，應收帳款不予計息。為減輕信用風險，本公司管理階層依公司相關之政策、程序及內部控制，指派專責團隊負責授信作業及其他監控程序，以確保逾期應收帳款之回收已採取適當行動，並按權責由管理階層負責授信額度之決定及授信核准。此外，本公司會定期逐一複核應收帳款之可回收金額以確保無法回收之應收帳款項已提列適當減損損失。

本公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量 GDP 預測及產業展望。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期，本公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

108 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期超過 90 天	合計
總帳面金額	$4,620,136	$ 768,649	$ 6,099	$ -	$ -	$5,394,884
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$4,620,136	$ 768,649	$ 6,099	$ -	$ -	$5,394,884

107 年 12 月 31 日

	未逾期	逾期 1～30 天	逾期 31～60 天	逾期 61～90 天	逾期超過 90 天	合計
總帳面金額	$4,653,894	$1,064,568	$ 430,803	$ 7,271	$ 224,323	$6,380,859
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$4,653,894	$1,064,568	$ 430,803	$ 7,271	$ 224,323	$6,380,859

九、存　　貨

	108年12月31日	107年12月31日
製成品	$ 542,260	$ 800,935
在製品	3,842,467	3,617,975
原　料	2,000,770	2,324,865
	$ 6,385,497	$ 6,743,775

108 及 107 年度與存貨相關之銷貨成本分別為 32,896,453 仟元及 34,633,514 仟元。

108 及 107 年度之銷貨成本包括實際產能使用較低所導致之未分攤固定製造費用分別為 3,064,643 仟元及 703,241 仟元，及分別提列存貨呆滯及跌價損失 350,932 仟元及 439,322 仟元。

十、採用權益法之投資貸餘

投資子公司

	108年12月31日	107年12月31日
非上市（櫃）公司		
Global Powertec Co., Ltd.（Global Powertec 公司）	$ 57,439	$ 41,961

本公司於資產負債表日對子公司之所有權權益及表決權百分比如下：

	108年12月31日	107年12月31日（重編後）
Global Powertec 公司	100%	100%

本公司為重整集團組織架構，於 108 年 4 月 1 日由本公司將持股 100%之富碩公司及 Sprout 公司全數出售予力晶公司；於 108 年 5 月 1 日由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec 公司依企業併購法讓與本公司。前述交易屬共同控制下組織重組，視為自始合併而追溯重編前期比較財務報表。請參閱本公司 108 年度合併財務報告附註十。

上述子公司之業務性質，主要營業場所及公司註冊之國家資訊，請參閱附表二「被投資公司資訊、所在地區…等相關資訊」附表。

本公司 108 及 107 年度採用權益法之子公司之損益及其他綜合損益份額，係依據子公司同期間經會計師查核之財務報告認列。

十一、不動產、廠房及設備

	108年12月31日
自　　用	$47,358,384

	108年12月31日	107年12月31日
房屋及建築	$ 4,380,121	$ 4,464,421
機器設備	31,651,873	25,363,513
研發設備	1,837,813	1,197,621
廠務設備	6,207,126	5,153,233
運輸設備	2,719	1,599
生財器具	80,465	80,304
其他設備	120,452	127,742
待驗設備及未完工程	3,077,815	4,298,694
	$47,358,384	$40,687,127

(一) 自用－108 年

	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				
	年初餘額	增加	出售或報廢	科目移轉	年底餘額
成本					
房屋及建築	$ 11,527,161	$ -	$ -	$ 133,532	$ 11,660,693
機器設備	201,763,144	-	(4,145,292)	9,956,481	207,574,333
研發設備	2,064,558	-	(5,918)	958,631	3,017,271
廠務設備	29,605,077	-	(5,138)	1,464,974	31,064,913
運輸設備	10,239	-	-	1,460	11,699
生財器具	603,003	-	(8,336)	37,130	631,797
其他設備	1,783,576	-	(4,626)	75,935	1,854,885
	247,356,758	$ -	($ 4,169,310)	$ 12,628,143	255,815,591
累計折舊					
房屋及建築	7,062,740	$ 217,832	$ -	$ -	7,280,572
機器設備	176,361,044	3,804,839	(4,088,777)	(193,233)	175,883,873
研發設備	866,937	126,983	(5,918)	191,456	1,179,458
廠務設備	24,451,844	411,078	(5,135)	-	24,857,787
運輸設備	8,640	340	-	-	8,980
生財器具	522,699	36,969	(8,336)	-	551,332
其他設備	1,655,834	81,798	(4,626)	1,427	1,734,433
	210,929,738	$ 4,679,839	($ 4,112,792)	($ 350)	211,496,435
累計減損					
機器設備	38,587	$ -	$ -	$ -	38,587
待驗設備及未完工程	4,298,694	$ 11,407,264	$ -	($ 12,628,143)	3,077,815
淨額	$ 40,687,127				$ 47,358,384

(二) 107 年

	107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				
	年初餘額	增加	出售或報廢	科目移轉	年底餘額
成本					
房屋及建築	$ 10,262,282	$ -	$ -	$ 1,264,879	$ 11,527,161
機器設備	195,955,302	-	(794,744)	6,602,586	201,763,144
研發設備	818,084	-	(1,039)	1,247,513	2,064,558
廠務設備	27,706,920	-	(4,398)	1,902,555	29,605,077
運輸設備	10,747	-	(508)	-	10,239
生財器具	563,143	-	(9,362)	49,222	603,003
租賃資產	3,328,288	-	-	(3,328,288)	-
其他設備	1,693,725	-	(4,289)	94,140	1,783,576
	240,338,491	$ -	($ 814,340)	$ 7,832,607	247,356,758

（接次頁）

（承前頁）

	107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				
	年初餘額	增加	出售或報廢	科目移轉	年底餘額
累計折舊					
房屋及建築	$ 6,885,974	$ 176,766	$ -	$ -	$ 7,062,740
機器設備	173,773,395	3,159,412	(793,608)	221,845	176,361,044
研發設備	486,481	49,015	(1,039)	332,480	866,937
廠務設備	24,190,339	265,641	(4,136)	-	24,451,844
運輸設備	8,829	319	(508)	-	8,640
生財器具	505,031	27,030	(9,362)	-	522,699
租賃資產	352,761	201,564	-	(554,325)	-
其他設備	1,613,501	46,622	(4,289)	-	1,655,834
	207,816,311	$ 3,926,369	($ 812,942)	$ -	210,929,738
累計減損					
機器設備	38,986	$ -	($ 399)	$ -	38,587
待驗設備及未完工程	2,445,763	$ 9,685,538	$ -	($ 7,832,607)	4,298,694
淨額	$ 34,928,957				$ 40,687,127

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

房屋及建築	21 至 40 年
機器設備	1.5 至 19 年
研發設備	1.5 至 19 年
廠務設備	6 至 30 年
運輸設備	6 年
生財器具	4 年
租賃資產	6 至 19 年
其他設備	4 年

本公司設定質押作為借款擔保之不動產、廠房及設備金額，請參閱附註十四及二八。

十二、租賃協議

(一) 使用權資產－108 年

	108年12月31日
使用權資產帳面金額	
土地	$ 1,523,791
建築物	149,983
機器設備	2,696,447
運輸設備	23,724
	$ 4,393,945

	108年度
使用權資產之增添	$ 2,768,430
使用權資產之折舊費用	
土　　地	$ 70,872
建 築 物	32,236
機器設備	55,120
運輸設備	9,656
	$ 167,884

(二) 租賃負債－108 年

	108年12月31日
租賃負債帳面金額	
流　　動	$ 215,566
非 流 動	$ 4,083,303

租賃負債之折現率區間如下：

	108年12月31日
土　　地	2.92%
建 築 物	1.79%~2.64%
機器設備	1.83%~4.58%
運輸設備	1.79%~1.97%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租若干土地及建築物做為廠房及辦公室使用，主要租賃期間為 20 年。位於中華民國之土地租賃約定每 2 年依公告地價調整租賃給付。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之土地及建築物並無優惠承購權。

本公司承租若干公務車以供營業使用，租賃期間為 3～4 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之公務車並無優惠承購權。

(四) 其他租賃資訊

108 年

	108年度
短期租賃費用	$ 11,367
租賃之現金流出總額（含使用權資產）	$153,335

本公司選擇對符合短期租賃之機器設備與公務車租賃適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

107 年

不可取消營業租賃之未來最低租賃給付總額如下：

	107年12月31日
不超過1年	$ 145,279
1～5年	544,161
超過5年	907,914
	$1,597,354

十三、無形資產

	108年12月31日	107年12月31日
技術移轉及授權費	$ 55,876	$320,696
專 利 權	136,454	166,800
電腦軟體設備及系統費	45,088	29,844
其　　他	4,310	9,584
	$241,728	$526,924

	技術移轉及授權費	電腦軟體設備及系統費	專利權	其他	合計
成　本					
108年1月1日餘額	$1,324,100	$ 181,298	$ 307,550	$ 27,699	$1,840,647
增　添	-	46,594	-	-	46,594
本期攤提完畢	-	(159,589)	-	(18,732)	(178,321)
108年12月31日餘額	$1,324,100	$ 68,303	$ 307,550	$ 8,967	$1,708,920
累計攤銷					
108年1月1日餘額	$1,003,404	$ 151,454	$ 140,750	$ 18,115	$1,313,723
攤銷費用	264,820	31,350	30,346	5,274	331,790
本期攤提完畢	-	(159,589)	-	(18,732)	(178,321)
108年12月31日餘額	$1,268,224	$ 23,215	$ 171,096	$ 4,657	$1,467,192
107年12月31日及108年1月1日淨額	$ 320,696	$ 29,844	$ 166,800	$ 9,584	$ 526,924
108年12月31日淨額	$ 55,876	$ 45,088	$ 136,454	$ 4,310	$ 241,728
成　本					
107年1月1日餘額	$1,324,100	$ 179,231	$ 307,550	$ 27,699	$1,838,580
增　添	-	15,782	-	-	15,782
本期攤提完畢	-	(13,715)	-	-	(13,715)
107年12月31日餘額	$1,324,100	$ 181,298	$ 307,550	$ 27,699	$1,840,647
累計攤銷					
107年1月1日餘額	$ 738,584	$ 134,534	$ 110,402	$ 11,734	$ 995,254
攤銷費用	264,820	30,635	30,348	6,381	332,184
本期攤提完畢	-	(13,715)	-	-	(13,715)
107年12月31日餘額	$1,003,404	$ 151,454	$ 140,750	$ 18,115	$1,313,723
107年12月31日淨額	$ 320,696	$ 29,844	$ 166,800	$ 9,584	$ 526,924

技術移轉及授權費主要係本公司支付予 Micron Memory Japan, Inc.（原 Elpida Memory Inc.）移轉及授權使用若干製造動態隨機存取記憶體技術之費用。

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

技術移轉及授權費	5 年
電腦軟體設備及系統費	2 年
專 利 權	10 至 15 年
其　　他	2 至 5 年

十四、借　　款

(一) 短期借款

	108年12月31日	107年12月31日
無擔保借款		
－銀行借款	$ -	$200,000
－關係人借款（參閱附註二七）	-	489,435
	$ -	$689,435

銀行借款之利率於 107 年 12 月 31 日為 1.85%。

(二) 長期借款

	108年12月31日	107年12月31日
擔保借款		
－長期抵押聯合貸款(一)	$20,064,077	$15,773,910
－長期抵押聯合貸款(二)	3,941,600	2,766,096
－長期抵押聯合貸款(三)	1,279,285	-
－中長期借款(四)	-	62,500
－其　　他	865,300	-
小　　計	26,150,262	18,602,506
無擔保借款		
－銀行借款	525,000	608,334
其他借款		
－其　　他	-	804,885
小　　計	525,000	1,413,219
	26,675,262	20,015,725
減：列為 1 年內到期部分	(5,512,049)	(4,580,670)
長期借款	$21,163,213	$15,435,055

力晶公司於 107 年 3 月 14 日簽署長期抵押聯合貸款(一)之授信合約、分別於 107 年 12 月 10 日及 108 年 12 月 25 日簽署第一次及第二次增補合約，授信額度變更為新臺幣 24,500,000 仟元。依聯貸合約約定按季還本，到期日為 112 年 12 月，108 年及 107 年 12 月 31 日有效利率皆為 1.79%。主要承諾事項如下：

1. 力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，將聯合授信合約下之權利義務，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予本公司，並自基準日起，本授信案由本公司擔任借款人。
2. 本公司需於額度管理銀行開立營運收支專戶該專戶之餘額應於每季末檢視當季累積存（匯）入金額不得低於新台幣 6,000,000 仟元或等值外幣。
3. 本公司於本授信案期間，每年資本支出加計非資本支出及現金股利之支出限額，不得超逾前一年度之稅後淨利加計折舊並扣除特別保留份額。非資本支出，係指包括借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款及與借款人本業相關之長、短期投資股票或股權支出。但借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款屬借新還舊者不在此限。前述支出限額，依第二次增補合約規定，109 年為一固定限額，自 110 年起則不得超逾前一期期末之稅後淨利減除重大無現金流量之收入，加計折舊並扣除特別保留份額。
4. 本公司於本授信案期間，每季需提供經額度管理銀行同意之會計師就資本支出、支出限額及相關約定之查核或檢核報告予額度管理銀行。
5. 於債務清償前，本公司之年度財務報表受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之限制。

本公司截至 108 年 12 月 31 日止之各項財務比率未符合合約規定。依合約約定期限內未予改善，需支付一定比例之補償費及罰款，則財務比率之違反不視為發生違約情事。

長期抵押聯合貸款(二)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 114 年 1 月，截至 108 年及 107 年 12 月 31 日有效利率分別為

1.86%及 1.96%。另聯貸合約規定，本公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之限制。本公司因 107 年度個體財務報告之流動比率小於 100%，惟已依貸款合約規定期限內完成改善。

長期抵押聯合貸款(三)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 113 年 2 月，截至 108 年 12 月 31 日有效利率為 1.86%。另聯貸合約規定，本公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有負債比率、流動比率及利息保障倍數等限制。本公司截至 108 年 12 月 31 日止之各項財務比率均符合合約規定。

中長期借款(四)依合約規定於每季償付至 108 年 7 月到期，截至 107 年 12 月 31 日止，有效年利率為 2.09%，前述借款已於 108 年 3 月提前清償完畢。

長期借款擔保之情形，請參閱附註二八。

力晶公司分別於 106 年 2 月、106 年 9 月及 106 年 12 月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約約定按季還本，到期日為 109 年 2 月至 109 年 12 月，部分借款已於 108 年 4 月提前清償。截至 108 年 12 月 31 日止，年利率為 1.71%至 2.04%。

力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於 108 年 4 月簽署中長期授信增補合約，將授信合約下之債務、權利及義務，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予本公司，並自基準日起，前述無擔保銀行中長期額度貸款由本公司擔任借款人。

本公司分別於 108 年 5 月及 108 年 7 月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約規定每半年還本，到期日分別為 111 年 5 月及 110 年 7 月，截至 108 年 12 月 31 日止，年利率皆為 1.60%。

其他借款：力晶公司於 106 年 5 月至 10 月與金士頓公司承作設備買賣融資借款，相關款項於到期日 108 年 10 月一次支付。依設備買賣融資需支付價款設算隱含利率約為 2.78%至 2.89%。力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予本公司，並自基準日起，本融資借款由本公司擔任借款人。前述借款於 108 年 9 月簽署增補合約，對方約定於 110 年 10 月

一次清償借款，截至 108 年 12 月 31 日止，年利率為 1.80%。擔保之情形請參閱附註二八。

十五、其他應付款

	108年12月31日	107年12月31日
應付薪資及獎金	$ 1,231,066	$ 1,416,294
應付權利金	488,941	339,407
應付電費	188,870	182,526
應付利息	31,946	25,201
應付員工及董監酬勞	-	2,350,650
其　　他	1,548,854	1,633,549
	$ 3,489,677	$ 5,947,627

十六、其他流動負債

	108年12月31日	107年12月31日
退款負債	$ 191,000	$ 159,277
存入保證金	161,647	-
其　　他	726,225	278,630
	$ 1,078,872	$ 437,907

十七、負債準備－流動

	108年12月31日	107年12月31日
訴訟案件	$ -	$234,389

	訴　訟　案　件
108 年 1 月 1 日餘額	$234,389
共同控制下前手權益轉出數	(234,389)
108 年 12 月 31 日餘額	$ -
107 年 1 月 1 日餘額	$200,000
本期新增	34,389
本期使用	-
107 年 12 月 31 日餘額	$234,389

訴訟案件係依最有可能之賠償金額並加計利息估計。

日本 Toshiba 公司於 103 年 5 月在台灣智慧財產法院控訴力晶公司等數名被告應連帶付給 Toshiba 公司新台幣 2 億元之專利侵權損害賠償金，於 106 年 7 月經智慧財產法院一審宣判應連帶給付賠償金及按年息百分之五計算之利息。力晶公司就此已提列等額之負債準備且

於 106 年 7 月 19 日至新竹地院提存所提 2 億元預供擔保以免假執行，並於 106 年 7 月 31 日進行上訴救濟。於 108 年 5 月 1 日進行母子間組織重組時，基於法律責任將前述負債準備及相關擔保保留於力晶公司。

十八、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

本公司適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

(二) 確定福利計畫

本公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。該等公司按員工每月薪資總額 2%提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，該等公司並無影響投資管理策略之權利。

列入個體資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	108年12月31日	107年12月31日
已提撥確定福利義務之現值	$ 2,605,324	$ 2,467,078
計畫資產公允價值	(1,040,191)	(892,586)
淨確定福利負債	$ 1,565,133	$ 1,574,492

淨確定福利負債變動如下：

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
107 年 1 月 1 日	$ 2,441,031	($ 797,426)	$ 1,643,605
當期服務成本	24,680	-	24,680
利息費用（收入）	30,116	(10,152)	19,964
認列於損益	54,796	(10,152)	44,644

（接次頁）

（承前頁）

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
再衡量數			
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	$ -	($ 21,055)	($ 21,055)
精算損失－人口統計假設變動	11,204	-	11,204
精算損失－財務假設變動	23,707	-	23,707
精算損失－經驗調整	1,425	-	1,425
認列於其他綜合損益	36,336	(21,055)	15,281
雇主提撥	-	(119,222)	(119,222)
福利支付	(65,085)	55,269	(9,816)
107 年 12 月 31 日	2,467,078	(892,586)	1,574,492
當期服務成本	17,760	-	17,760
利息費用（收入）	14,696	(5,239)	9,457
認列於損益	32,456	(5,239)	27,217
再衡量數			
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	-	(991)	(991)
精算損失－人口統計假設變動	3,943	-	3,943
精算損失－財務假設變動	115,082	-	115,082
精算損失－經驗調整	(7,109)	-	(7,109)
認列於其他綜合損益	111,916	(991)	110,925
雇主提撥	-	(72,834)	(72,834)
福利支付	(21,135)	6,989	(14,146)
認列人口併入影響數	15,009	(75,530)	(60,521)
108 年 12 月 31 日	$ 2,605,324	($ 1,040,191)	$ 1,565,133

本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不

低於當地銀行 2 年定期存款利率。如有低於該利率之情形，由國庫補足。

2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

本公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	108年12月31日	107年12月31日
折 現 率	0.75%	1.00%
薪資預期增加率	4.25%	3.00%~4.25%
離 職 率	0.71%	0.53%~1.23%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	108年12月31日	107年12月31日
折 現 率		
增加 0.25%	($ 87,141)	($ 84,815)
減少 0.25%	$ 91,170	$ 88,856
薪資預期增加率		
增加 0.25%	$ 85,929	$ 83,719
減少 0.25%	($ 82,667)	($ 80,414)
離 職 率		
離職率 110%	($ 1,411)	($ 1,509)
離職率 90%	$ 1,415	$ 1,514

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	108年12月31日	107年12月31日
預期 1 年內提撥金額	$ 39,360	$131,466
確定福利義務加權平均存續期間	13 年	13 年~14 年

十九、權　　益

(一) 普通股股本

	108年12月31日	107年12月31日
額定股數（仟股）	5,000,000	1,000,000
額定股本	$50,000,000	$10,000,000
已發行且已收足股款之股數（仟股）	3,105,196	358,667
已發行股本	$31,051,965	$ 3,586,674

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為 500,000 仟股。

本公司股本變動主要係因股票股利、組織重組及現金增資發行新股。

本公司於 107 年 9 月 4 日董事會決議，為進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業（含資產、負債及營業），並由本公司發行新股予力晶公司作為收購之對價，計發行新股 2,260,818 仟股，並以 108 年 5 月 7 日為收購發行新股增資基準日，已於 108 年 5 月 13 日辦理變更登記完竣。

本公司經董事會決議現金增資發行新股，並於 108 年 6 月 28 日經董事會決議調整最終股數及募集金額，辦理現金增資發行新股 400,000 仟股，每股面額 10 元，並以每股新台幣 10.1 元發行，本次以 108 年 9 月 20 日為增資基準日。

上述現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數之 13.5%由員工認購，其餘之 86.5%計 346,000 仟股，依本公司原股東力晶公司 108 年度股東常會決議將其認購權利讓與力晶公司全體股東。

本公司經 108 年 12 月 24 日董事會決議發行員工認股權憑證 150,000 仟單位，每單位認股權憑證得認購之股數為普通股 1 股。經金管會申報生效並核准發行，並於 109 年 1 月 20 日董事會決議第一階段發行員工認股權憑證 138,440 仟單位。

(二) 資本公積

	108年12月31日	107年12月31日
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)		
股票發行溢價	$170,680	$ 89,200
僅得用以彌補虧損		
員工認股權執行轉入之金額	11,247	-
	$181,927	$ 89,200

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利

依本公司 108 年 3 月 12 日修正後章程之盈餘分派政策規定，本公司盈餘分派或虧損彌補得於每半會計年度終了後為之。每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後之。本公司章程規定之員工及董監事酬勞分派政策，參閱附註二一之(七)員工酬勞及董監事酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司於 108 年 4 月 12 日及 107 年 5 月 10 日董事會（代行股東會職權），分別決議通過 107 及 106 年度盈餘分配案如下：

盈餘分配表	107年度	106年度
法定盈餘公積	$ 98,593	$ 58,115
現金股利	95,234	-
股票股利	857,109	523,032
每股現金股利（元）	0.27	-
每股股票股利（元）	2.39	1.71

本公司於 109 年 3 月 9 日董事會擬議虧損撥補案，尚待預計於 109 年 5 月 27 日召開之股東常會決議。

(四) 其他權益項目

其他權益項目之變動數如下：

108 年度

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計
年初餘額	($ 4,316)	$ 356	($ 3,960)
採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額	(294)	39,775	39,481
共同控制下後手由本公司業主權益轉出	4,316	(40,131)	(35,815)
年底餘額	($ 294)	$ -	($ 294)

107 年度

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計
年初餘額（國際會計準則第 39 號）	($ 4,127)	$ 53,136	$ -	$ 49,009
追溯適用國際財務報導準則第 9 號之影響數	-	(53,136)	(70,724)	(123,860)
調整後期初餘額（國際財務報導準則第 9 號）	(4,127)	-	(70,724)	(74,851)
換算國外營運機構財務報表所產生之兌換差額	(189)	-	-	(189)
權益工具未實現評價損益	-	-	2,892	2,892
採用權益法認列之子公司之其他綜合損益份額	-	-	26,397	26,397
處分權益工具累計損益移轉至保留盈餘	-	-	41,791	41,791
年底餘額	($ 4,316)	$ -	$ 356	($ 3,960)

二十、營業收入

	108年度	107年度
客戶合約收入		
商品銷售收入	$35,897,121	$49,913,779

(一) 合約餘額

	108年12月31日	107年12月31日	107年1月1日
應收帳款（附註八）	$ 5,394,884	$ 6,380,859	$ 5,365,698
合約負債			
商品銷售	$ 808,913	$ 1,138,000	$ 528,081
其　　他	117,446	117,598	44,316
	$ 926,359	$ 1,255,598	$ 572,397

來自年初合約負債以及前期已滿足之履約義務於當期認列為收入之金額如下：

	108年度	107年度
來自年初合約負債		
銷貨商品	$715,386	$438,410
其他（帳列其他收益及費損淨額）	46,922	32,866
	$762,308	$471,276

(二) 客戶合約收入之細分

商品銷貨收入依主要產品項目細分

	108年度	107年度
主要地區市場		
台　　灣	$23,480,915	$30,730,668
中　　國	2,223,105	3,173,691
日　　本	1,487,232	3,808,830
其　　他	8,705,869	12,200,590
	$35,897,121	$49,913,779
產品項目		
包裝元件	$ 382,834	$ 216,922
晶　　圓	35,514,287	49,244,787
其　　他	-	452,070
	$35,897,121	$49,913,779

二一、本年度淨（損）利

(一) 其他收益及費損淨額

	108年度	107年度
賠償收入	$141,987	$ 2,412
處分及報廢不動產、廠房及設備淨益	950	15,983
其他收入及支出	29,078	238,553
	$172,015	$256,948

(二) 其他收入

	108年度	107年度
利息收入	$ 62,531	$ 91,943
股利收入	-	610
	$ 62,531	$ 92,553

(三) 其他利益及損失

	108年度	107年度
外幣兌換淨（損）益	($ 76,809)	$153,267
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨益（損）	12,784	(39,512)
	($ 64,025)	$113,755

(四) 財務成本

	108年度	107年度
借款之利息	$437,244	$405,859
租賃負債之利息	75,849	-
應付租賃款之利息	-	49,562
其　　他	1	6
	$513,094	$455,427

利息資本化相關資訊如下：

	108年度	107年度
利息資本化金額	$ 72,899	$ 58,746
利息資本化利率	1.84%~1.98%	1.85%~2.39%

(五) 折舊及攤銷

	108年度	107年度
不動產、廠房及設備	$ 4,679,839	$ 3,926,369
使用權資產	167,884	-
無形資產	331,790	332,184
合　　計	$ 5,179,513	$ 4,258,553
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	$ 4,521,636	$ 3,780,769
營業費用	325,800	144,689
其他收益及費用	287	911
	$ 4,847,723	$ 3,926,369
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	$ 318,401	$ 318,772
營業費用	13,389	13,412
	$ 331,790	$ 332,184

(六) 員工福利費用

	108年度	107年度
退職後福利		
確定提撥計畫	$ 320,001	$ 308,063
確定福利計畫（附註十八）	27,217	44,644
	347,218	352,707
股份基礎給付		
權益交割	11,247	-
其他員工福利	7,615,105	11,459,422
員工福利費用合計	$ 7,973,570	$ 11,812,129
依功能別彙總		
營業成本	$ 5,298,929	$ 7,853,230
營業費用	2,674,641	3,958,899
	$ 7,973,570	$ 11,812,129

(七) 員工酬勞及董監事酬勞

本公司係以當年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本公司稅前淨利，應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

108 年度係為稅前淨損，擬不估列員工酬勞及董監事酬勞。

107 年度員工酬勞及董監事酬勞於 108 年 2 月 12 日經董事會決議如下：

金　　額

	107年度	
	現　　金	股　　票
員工酬勞	$178,129	$　-
董監事酬勞	39,293	-

年度個體財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

107 及 106 年度員工酬勞及董監事酬勞之實際配發金額與 107 及 106 年度個體財務報告之認列金額並無差異。

二二、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅費用主要組成項目

	108年度	107年度
當期所得稅		
本年度產生者	$　6,168	$　43,440
未分配盈餘加徵	-	200,208
以前年度之調整	(　1,321)	69,410
	4,847	313,058
遞延所得稅		
當年度產生者	536,517	(　323,220)
稅率變動	-	(　252,253)
與所得稅抵減有關	(　515,917)	1,984,300
	20,600	1,408,827
認列於損益之所得稅費用	$　25,447	$ 1,721,885

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	108年度	107年度
本年度稅前淨（損）利	($　2,617,737)	$　8,636,629
稅前淨（損）利按法定稅率計算之稅額	($　528,445)	$　2,679,782
調節項目之所得稅影響數		
決定課稅所得時不可計入之損益	15,729	103,875

（接次頁）

（承前頁）

	108年度	107年度
遞延所得稅資產／負債之所得稅影響數	$ 533,316	($ 1,064,326)
遞延所得稅資產／負債之稅率變動影響數	-	(275,006)
本年度產生者	6,168	6,426
未分配盈餘加徵	-	200,208
以前年度之調整	(1,321)	70,926
認列於損益之所得稅費用	$ 25,447	$ 1,721,885

我國於 107 年修正中華民國所得稅法，將營利事業所得稅稅率由 17%調整為 20%。該修正並規定 107 年度未分配盈餘所適用之稅率將由 10%調降為 5%。

(二) 本期所得稅資產與負債

	108年12月31日	107年12月31日
本期所得稅資產		
應收退稅款	$ 11,878	$ 7,218
本期所得稅負債		
應付所得稅	$ -	$200,208

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

108 年度

	年初餘額	共同控制下前手權益轉出數	認列於損益	年底餘額
遞延所得稅資產				
虧損扣抵	$ 10,804,272	($ 10,739,917)	$ 415,210	$ 479,565
暫時性差異				
折舊	56,831	-	72,592	129,423
備抵存貨跌價損失	178,992	(176,029)	246,216	249,179
其他	1,115,579	(1,083,405)	290,920	323,094
備抵評價	(10,374,964)	10,322,749	(508,460)	(560,675)
	$ 1,780,710	($ 1,676,602)	$ 516,478	$ 620,586
遞延所得稅負債				
暫時性差異				
不動產、廠房及設備	$ 1,752,678	($ 1,671,567)	$ 526,685	$ 607,796
其他	7,432	(5,035)	10,393	12,790
	$ 1,760,110	($ 1,676,602)	$ 537,078	$ 620,586

107 年度

	年初餘額	認列於損益	年底餘額
遞延所得稅資產			
虧損扣抵	$ 12,255,301	($ 1,451,029)	$ 10,804,272
暫時性差異			
折舊	111,725	(54,894)	56,831
備抵存貨跌價損失	77,459	101,533	178,992
其他	1,795,960	(680,381)	1,115,579
備抵評價	(11,039,633)	664,669	(10,374,964)
	$ 3,200,812	($ 1,420,102)	$ 1,780,710
遞延所得稅負債			
暫時性差異			
不動產、廠房及設備	$ 1,753,663	($ 985)	$ 1,752,678
其他	17,722	(10,290)	7,432
	$ 1,771,385	($ 11,275)	$ 1,760,110

(四) 未於個體資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異及未使用虧損扣抵金額

	108年12月31日	107年12月31日
虧損扣抵金額	$ -	$ 45,118,730
可減除暫時性差異金額	$ 705,104	$ 6,756,089

(五) 未使用之虧損扣抵及免稅相關資訊

截至 108 年 12 月 31 日止，虧損扣抵相關資訊如下：

尚未扣抵餘額	最後扣抵年度
$ 2,397,828	118 年度

(六) 所得稅核定情形

本公司截至 106 年度以前之營利事業所得稅申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二三、每股（虧損）盈餘

單位：每股元

	108年度	107年度
基本每股（虧損）盈餘	($ 0.94)	$ 2.56
稀釋每股（虧損）盈餘	($ 0.94)	$ 2.54

計算每股（虧損）盈餘時，依附註一所述本公司於 108 年 5 月 1 日進行母子間組織重組，並由本公司發行新股予力晶公司作為收購之對價，係屬共同控制下之組織重組，應視為自始即已合併而追溯前期股數。另本公司無償配股之影響業已追溯調整，該無償配股基準日訂於 108 年 4 月 22 日，因追溯調整，107 年度之基本及稀釋每股盈餘變動如下：

單位：每股元

	追溯調整前	追溯調整後
基本每股盈餘	$ 2.75	$ 2.56
稀釋每股盈餘	$ 2.64	$ 2.54

用以計算每股（虧損）盈餘及普通股加權平均股數如下：

本年度淨（損）利

	108年度	107年度
歸屬於本公司業主之淨（損）利	($ 1,480,370)	$ 985,928
歸屬於共同控制下前手權益淨（損）利	(1,162,814)	5,890,576
歸屬於共同控制下後手權益淨損（利）	-	38,240
用以計算基本及稀釋每股（虧損）盈餘之淨（損）利	($ 2,643,184)	$ 6,914,744

股　　數

單位：仟股

	108年度	107年度
用以計算基本每股（虧損）盈餘之普通股加權平均股數	2,821,863	2,705,197
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工酬勞	-	18,388
用以計算稀釋每股（虧損）盈餘之普通股加權平均股數	2,821,863	2,723,585

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

本公司員工酬勞若採發放股票方式，因具反稀釋作用，故未納入稀釋每股虧損之計算。

二四、股份基礎給付協議

現金增資保留員工認股

本公司經董事會決議現金增資發行新股，並於 108 年 6 月 28 日經董事會決議調整最終發行股數及募集金額，並依據公司法保留新股總數 13.5%計 54,000 仟股由員工認購。員工認購不足一股之畸零股或放棄認股之股份，則授權董事長洽特定人認購之。

本公司於 108 年 7 月 16 日給與之員工認股權，其公平價值使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之參數如下：

衡量日每股股權公平價值	$ 9.89
行使價格	10.10
預期波動率	30.58%
預期存續期間	0.062 年
預期股利率	0.00%
無風險利率	0.48%
認股權公平價值	0.2083

本公司 108 年度因現金增資保留員工認購權利認列之酬勞成本為 11,247 仟元。

二五、資本風險管理

本公司進行資本管理係確保公司能夠於繼續經營之前提下，藉由將債務與權益餘額最適化，以使股東報酬極大化。

本公司資本結構係由本公司之淨債務（即借款減除現金及約當現金）、歸屬於母公司業主之權益（即股本、資本公積、保留盈餘及其他權益項目）及非控制權益組成。

二六、金融工具

(一) 公允價值之資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

108 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 4,372	$ -	$ 4,372
透過損益按公允價值衡量之金融負債				
衍生工具	$ -	$ -	$ -	$ -

107 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 7,151	$ -	$ 7,151
透過損益按公允價值衡量之金融負債				
衍生工具	$ -	$ 81	$ -	$ 81

108 及 107 年度無第 1 等級與第 2 等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 金融工具以第 3 等級公允價值衡量之調節

107 年度

金融資產	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 權益工具
年初餘額	$ 14,869
認列於其他綜合損益(透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益)	2,892
本年度處分	(17,761)
年底餘額	$ -

3. 第 2 等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具－遠期外匯合約	現金流量折現法：按期末之可觀察遠期匯率及合約所訂匯率估計未來現金流量，並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

4. 第 3 等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

國內未上市（櫃）權益投資係採淨市場法，係以可類比標的之交易價格為依據，依據標的公司及市場同業之財務資料，以市場乘數例如本益比、股價淨值比、股價營收比或其他財務比率來分析評價。

(三) 金融工具之種類

	108年12月31日	107年12月31日
金融資產		
強制透過損益按公允價值衡量	$ 4,372	$ 7,151
按攤銷後成本衡量之金融資產（註1）	11,729,501	15,573,614
金融負債		
透過損益按公允價值衡量		
持有供交易	-	81
按攤銷後成本衡量（註2）	39,335,353	32,186,033

註 1： 餘額係包含現金及約當現金、應收帳款－非關係人淨額、應收帳款－關係人淨額、其他應收款、其他金融資產及存出保證金等按以攤銷後成本衡量之金融資產。

註 2： 餘額係包含短期借款、應付帳款－非關係人、應付設備款、其他應付款、一年內到期之長期借款、租賃負債、長期借款及存入保證金等以攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

本公司之財務風險管理目標，係為管理與營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本公司致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司對於前述財務風險管理已依相關規範建立適當之政策、程序及內部控制，重要財務活動須經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。公司恪遵相關財務操作程序。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）及利率變動風險（參閱下述(2)）。本公司從事衍生金融工具（包括遠期外匯）以管理所承擔之外幣匯率。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而產生匯率變動風險。本公司匯率風險之管理採部分自然避險，並於政策許可之範圍內，利用遠期外匯合約管理風險。本公司之匯率風險管理，以避險為目的，不以獲利為目的。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含財務報表中已沖銷之非貨幣性計價之貨幣性項目），參閱附註三一。

敏感度分析

本公司主要受到美金、日幣、歐元及人民幣匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少 1%時，本公司之敏感度分析。敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其年末之換算以匯率變動 1%予以調整。敏感度分析之範圍包括現金及約當現金、應收帳款（含關係人）、其他應收款、應付帳款、應付設備款、租賃負債、其他應付款及借款。下表之正數係表示當新台幣相對於各相關貨幣貶值 1%時，將使稅前淨利增加之金額；當新台幣相對於各相關貨幣升值 1%時，其對稅前淨利之影響將為同金額之負數。

	美金之影響		日幣之影響		歐元之影響		人民幣之影響	
	108年度	107年度	108年度	107年度	108年度	107年度	108年度	107年度
損益	$ 19,894	$ 36,452	($ 4,056)	($ 4,363)	($ 307)	($ 297)	$ 130	$ 417

(2) 利率風險

因本公司內同時以固定及浮動利率借入資金，因而產生利率暴險。本公司定期評估避險活動，以確保採用最符合成本效益之避險策略。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	108年12月31日	107年12月31日
具公允價值利率風險		
一金融資產	$ 4,008,226	$ 5,568,852
一金融負債	(5,164,169)	(1,294,320)
具現金流量利率風險		
一金融資產	1,850,085	2,952,865
一金融負債	(25,809,962)	(19,410,840)

敏感度分析

有關利率風險之敏感性分析，主要針對資產負債表日浮動利率金融負債之現金流量變動為計算基礎。

若利率增加／減少 0.1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 108 及 107 年度之稅前淨利將分別減少／增加 23,960 仟元及 16,458 仟元，主因為本公司之浮動利率淨負債利率暴險。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務及本公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於資產負債表所認列之金融資產帳面金額。

為減輕信用風險，本公司已訂定授信及應收帳款管理辦法，以確保應收帳款之收回，以及逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司會每季逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。

本公司應收帳款之對象涵蓋眾多客戶，分散於不同產業及地理區域。本公司持續地針對應收帳款客戶之財務狀況每年或不定期進行評估。

個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、信評機構評等、本公司內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。本公司定期或不定期針對應收帳款客戶之財務狀況進行評估，必要時亦會要求客戶提供預收貨款、產能保證金、質押定存或其他擔保品，以降低特定客戶的信用風險。

另因流動資金及衍生金融工具之交易對方係信用良好之銀行，故該信用風險係屬有限。

3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應營運並減輕現金流量波動之影響。

銀行借款對本公司而言係為一項主要流動性風險來源。截至 108 年及 107 年 12 月 31 日止，本公司未動用之融資額度，參閱下列(3)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依本公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。因此，本公司可被要求立即還款之銀行借款，係列於下表最早之期間內，不考慮銀行立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

108 年 12 月 31 日

	1 年以下	1 ～ 5 年	5 年以上	合計
非衍生金融負債				
無附息負債	$ 8,061,354	$ -	$ -	$ 8,061,354
租賃負債	301,111	2,452,181	2,480,436	5,233,728
浮動利率工具	5,539,868	19,414,805	923,800	25,878,473
固定利率工具	15,575	880,833	-	896,408
	$13,917,908	$22,747,819	$ 3,404,236	$40,069,963

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1 年 以 內	1 ～ 5 年	5 ～ 1 0 年	1 0 ～ 1 5 年	1 5 ～ 2 0 年	2 0 年 以 上
租賃負債	$ 301,111	$ 2,452,181	$ 1,361,842	$ 481,923	$ 442,115	$ 194,556

107 年 12 月 31 日

	0 ～ 3 個 月	4 ～ 6 個 月	7個月～1年	1 ～ 5 年	5 年 以 上	合 計
非衍生金融負債						
無附息負債	$ 8,549,470	$ 2,460,985	$ 552,964	$ -	$ -	$11,563,419
浮動利率工具	1,103,809	1,103,809	1,786,785	12,902,614	2,580,000	19,477,017
固定利率工具	250,000	-	1,063,530	-	-	1,313,530
	$ 9,903,279	$ 3,564,794	$ 3,403,279	$12,902,614	$ 2,580,000	$32,353,966

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

(2) 衍生金融負債之流動性及利率風險表

針對衍生金融工具之流動性分析，就採淨額交割之衍生工具而言，係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製；就採總額交割之衍生工具而言，係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。

108 年 12 月 31 日

	0 ～ 3 個 月	4 ～ 6 個 月	7個月～1年	1 至 5 年	5 年 以 上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流 出	($ 565,342)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流 入	569,714	-	-	-	-
	$ 4,372	$ -	$ -	$ -	$ -

107 年 12 月 31 日

	0 ～ 3 個 月	4 ～ 6 個 月	7個月～1年	1 至 5 年	5 年 以 上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流 出	($1,928,637)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流 入	1,935,707	-	-	-	-
	$ 7,070	$ -	$ -	$ -	$ -

(3) 融資額度

	108年12月31日	107年12月31日
無擔保金融業及非金融業透支額度		
一已動用金額	$ 525,000	$ 2,102,654
一未動用金額	2,300,000	1,200,000
	$ 2,825,000	$ 3,302,654

（接次頁）

（承前頁）

	108年12月31日	107年12月31日
有擔保金融業及非金融業透支額度		
－已動用金額	$26,150,262	$18,602,506
－未動用金額	2,466,000	13,593,800
	$28,616,262	$32,196,306

二七、關係人交易

本公司與關係人間之交易如下：

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
力晶公司	本公司之母公司
PowerMemory Inc.	子公司
黃崇仁	主要管理階層
蔡國智	主要管理階層
力旺電子股份有限公司	實質關係人（力晶公司 107 年 5 月 24 日董監事改選後為非關係人）
力積電子股份有限公司	實質關係人（本公司 107 年 9 月 4 日董監事改選後為非關係人）
優立有限公司	實質關係人（108 年 8 月 14 日起為非關係人）
智安電子股份有限公司	實質關係人(107 年 12 月 24 日董監事改選後為非關係人）
力智電子股份有限公司	實質關係人（107 年 6 月 11 日董監事改選後為非關係人）
力祥半導體股份有限公司	實質關係人（107 年 6 月 11 日董監事改選後為非關係人）
愛普科技股份有限公司	實質關係人（本公司 107 年 9 月 4 日董監事改選後為非關係人）
智旺科技股份有限公司	實質關係人
智立投資股份有限公司	實質關係人
智豐科技股份有限公司	實質關係人
台灣光罩股份有限公司	實質關係人
黃毓秀	實質關係人
財團法人力晶文化基金會	實質關係人
Zentel Japan Corporation	實質關係人
力新國際科技股份有限公司	實質關係人
智仁科技開發股份有限公司	關聯企業

（接次頁）

（承前頁）

關係人名稱	與本公司之關係
力信投資股份有限公司	關聯企業
世仁投資股份有限公司	關聯企業
智典國際股份有限公司	關聯企業
世成科技股份有限公司	關聯企業
智成電子股份有限公司	關聯企業
合肥晶合集成電路有限公司	關聯企業

(二) 營業收入

	108年度	107年度
實質關係人	$ 1,656,474	$ 5,712,105
關聯企業	214	-
	$ 1,656,688	$ 5,712,105

(三) 進　　貨

	108年度	107年度
母公司	$ 1,353	$ -

(四) 出售存貨及設備維修備品

	108年度	107年度
關聯企業	$ -	$ 126

(五) 銷貨成本—權利金

	108年度	107年度
實質關係人	$ -	$ 31,351
關聯企業	18,900	62,399
	$ 18,900	$ 93,750

(六) 製造費用

	108年度	107年度
實質關係人	$ 340	$ 168

(七) 管理費用

	108年度	107年度
主要管理階層	$ -	$ 84
實質關係人	1,470	62,815
關聯企業	581	13,909
	$ 2,051	$ 76,808

(八) 研發費用

	108年度	107年度
子 公 司	$ 98,945	$ 95,337
實質關係人	206	2,702
關聯企業	101,712	101,661
	$200,863	$199,700

(九) 其他收益及費損淨額

	108年度	107年度
主要管理階層	$ 1	$ -
實質關係人	7,548	15,791
關聯企業	1,637	88,978
	$ 9,186	$104,769

(十) 應收帳款

	108年12月31日	107年12月31日
實質關係人	$ 49,914	$129,542

(十一) 其他應收款

	108年12月31日	107年12月31日
關聯企業	$ -	$ 61,645

(十二) 向關係人借款（帳列短期借款）:

	108年12月31日	107年12月31日
關聯企業	$ -	$489,435

財務成本

	108年度	107年度
關聯企業	$ 1,641	$ 16,871

本公司向關係人借款之借款利率於 107 年 12 月 31 日為 2.50%。上列借款皆為無擔保借款。

(十三) 其他應付款

	108年12月31日	107年12月31日
主要管理階層	$ 2,201	$ -
實質關係人	84	327
關聯企業	114,988	137,907
	$117,273	$138,234

(十四) 合約負債

	108年12月31日	107年12月31日
實質關係人	$ -	$ 235
關聯企業	-	59,970
	$ -	$ 60,205

(十五) 存出保證金

	108年12月31日	107年12月31日
主要管理階層	$ 1	$ 1
實質關係人	1	1
	$ 2	$ 2

(十六) 存入保證金

	108年12月31日	107年12月31日
實質關係人	$ -	$ 414
關聯企業	-	226
	$ -	$ 640

本公司與關係人間晶圓代工之銷貨價格，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人間之權利金、進貨價格、存貨及設備維修備品出售，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人之製造費用、管理費用及研發費用係依雙方議定之合作協議，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人間之其他收益及費損，係依據雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

上述之其他應收關係人款項主要係服務收入產生。

上述之其他應付關係人款項主要係權利金費用及技術開發費產生。

本公司合約負債之銷貨條件，係與客戶交易時參考市場行情，議定價格及數量。

本公司與關係人收取之存入保證金，主要係押金。

除上述交易外，本公司與其他關係人間之交易，係按一般交易條件及價格辦理。

(十七) 承租協議

關係人類別／名稱	108年度	107年度
取得使用權資產		
實質關係人	$ 4,946	$ -

帳列項目	關係人類別／名稱	108年12月31日
租賃負債－流動	主要管理階層	$ 80
	實質關係人	2,619
	關聯企業	6,911
		$ 9,610
租賃負債－非流動	主要管理階層	$ 245
	實質關係人	1,916
	關聯企業	21,100
		$ 23,261

關係人類別／名稱	關係人類別／名稱	108年度
財務成本	主要管理階層	$ 9
	實質關係人	51
	關聯企業	898
		$ 958

關係人類別／名稱	關係人類別／名稱	107年度
租賃費用	主要管理階層	$ 84
	實質關係人	2,736
	關聯企業	12,844
		$ 15,664

本公司向關係人承租辦公室、停車位及公務車，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金按月支付。

(十八) 主要管理階層薪酬

108 及 107 年度對董事及其他主要管理階層之薪酬總額如下：

	108年度	107年度
短期員工福利	$ 160,663	$ 1,063,933
退職後福利	22,723	-
	$ 183,386	$ 1,063,933

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、質抵押之資產

本公司下列資產已提供作為長期借款、天然氣使用、承租科管局土地及保稅品出區之擔保品：

	108年12月31日	107年12月31日
不動產、廠房及設備	$ 27,454,063	$ 20,023,645
受限制存款（帳列其他金融資產）	1,896,531	1,624,879
	$ 29,350,594	$ 21,648,524

二九、重大或有負債及未認列之合約承諾

除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

(一) 本公司分別於 92 年 8 月、94 年 3 月、97 年 6 月、99 年 3 月、10 月、100 年 7 月及 102 年 7 月與 Micron Memory Japan, Inc.（原 Elpida Memory Inc.）簽署若干動態隨機存取記憶體技術移轉與授權合約，本公司承諾自技術移轉完成後 5 年內支付一定金額之技術授權費及依約定產品之售價給付一定比例之權利金。惟雙方另於 100 年 5 月及 102 年 7 月簽署合作協議，修訂權利金支付比例。

(二) 本公司分別於 92 年 8 月及 94 年 3 月與某公司簽署若干動態隨機存取記憶體技術之專利授權合約，本公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(三) 本公司於 92 年 8 月與某公司等簽署若干動態隨機存取記憶體之專利技術授權合約，本公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(四) 本公司與某公司簽訂長期矽原料進貨合約，以確保矽原料穩定供貨，其中約定本公司須購買之相關最低數量及價格。

(五) 本公司於 108 年 7 月與愛爾蘭商遠東金士頓公司簽訂代工合約至 110 年 10 月 31 日止，本公司承諾以約定價格為其製造記憶體產品。

(六) 本公司與客戶 Mitsubishi Electric Corporation 簽訂晶圓製造合約，其中針對晶圓製造的部分機器設備，係由該公司提供，本公司需負保管及使用之責。

前述(一)至(四)之權利義務於收購轉讓基準日(即 108 年 5 月 1 日)由力晶公司轉讓予本公司。

三十、其　　他

本公司為重整集團組織架構，依附註一所述交易因屬共同控制下之組織重組，應視為自始即已合併而追溯重編前期比較財務報表。

經重編 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表，其影響如下：

個體資產負債表

	107年12月31日		
會　計　項　目	重編前金額	影響金額	重編後金額
資　產			
流動資產	$ 3,388,863	$ 18,888,027	$ 22,276,890
非流動資產	8,489,468	36,764,794	45,254,262
資產總計	$ 11,878,331	$ 55,652,821	$ 67,531,152
負債及權益			
流動負債	$ 3,947,176	$ 14,620,865	$ 18,568,041
非流動負債	3,068,742	15,933,562	19,002,304
負債總計	$ 7,015,918	$ 30,554,427	$ 37,570,345
權　益			
股　本	$ 3,586,674	$ -	$ 3,586,674
資本公積	89,200	-	89,200
保留盈餘	1,190,499	-	1,190,499
其他權益	(3,960)	-	(3,960)
本公司業主之權益	4,862,413	-	4,862,413
共同控制下前手權益	-	25,295,906	25,295,906
共同控制下後手權益	-	(197,512)	(197,512)
權益總計	4,862,413	25,098,394	29,960,807
負債與權益總計	$ 11,878,331	$ 55,652,821	$ 67,531,152

個體綜合損益表

會計項目	107年1月1日至12月31日 重編前金額	影響金額	重編後金額
營業收入	$ 7,637,436	$ 42,276,343	$ 49,913,779
營業成本	5,633,929	28,999,585	34,633,514
營業費用	1,568,828	5,088,295	6,657,123
其他收益及費損淨額	682,148	(425,200)	256,948
營業外收入及支出	(24,475)	(218,986)	(243,461)
所得稅費用	106,424	1,615,461	1,721,885
本期淨利	985,928	5,928,816	6,914,744
其他綜合損益	12,552	(24,595)	(12,043)
本期綜合損益總額	$ 998,480	$ 5,904,221	$ 6,902,701

三一、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本公司功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債如下：

	108年12月31日			107年12月31日		
	外幣	匯率	新台幣	外幣	匯率	新台幣
外幣資產						
貨幣性項目						
美金	$ 225,863	30.046	$6,786,284	$ 228,972	30.73	$7,036,321
歐元	58	33.66	1,944	274	35.21	9,674
日幣	941,145	0.2766	260,321	778,512	0.2783	216,660
人民幣	3,006	4.31	12,955	9,301	4.48	41,670
外幣負債						
貨幣性項目						
美金	159,650	30.046	4,796,840	110,351	30.73	3,391,089
歐元	969	33.66	32,606	1,117	35.21	39,328
日幣	2,407,362	0.2766	665,876	2,346,177	0.2783	652,941

本公司主要承擔美金及新台幣之外幣匯率風險。以下資訊係按持有外幣個體之功能性貨幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等功能性貨幣換算至表達貨幣之匯率。具重大影響之外幣兌換損益（已實現及未實現）如下：

	108年度		107年度	
功能性貨幣	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益
新台幣	1（新台幣：新台幣）	($ 76,809)	1（新台幣：新台幣）	$ 153,267

三二、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊：

1. 資金貸與他人。(無)
2. 為他人背書保證。(無)
3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)。(無)
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上。(無)
5. 取得不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上。(無)
6. 處分不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上。(無)
7. 與關係人進、銷貨之金額達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。(附表一)
8. 應收關係人款項達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。(無)
9. 從事衍生工具交易。(本公司從事衍生性商品相關資訊請參閱附註七及二六)
10. 被投資公司資訊、所在地區…等相關資訊。(附表二)

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。(無)
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益。(無)

力晶積成電子製造股份有限公司

與關係人進、銷貨交易金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：新台幣仟元

進（銷）貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收（付）票據、帳款		備註
			進／銷貨	金額	佔總進／銷貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率	
本公司	智豐科技股份有限公司	實質關係人	銷貨	$ 1,605,063	4.47%	註 1	$ -	—	$ -	-	註 2

註 1： 主要係月結 60 天付款。

註 2： 本公司為重整集團組織架構，於 108 年 5 月 1 日收購母公司力晶公司晶圓相關業務，故銷貨金額係包含 108 年 5 月 1 日前力晶公司銷售予智豐科技股份有限公司之金額。

力晶積成電子製造股份有限公司

被投資公司資訊、所在地區...等相關資訊

民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表二

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數（仟股）	比率（%）	帳面金額			
本公司	Global Powertec Co., Ltd.	英屬維京群島	從事各式投資業務	$ 1	$ 1	-	100.00	($ 57,439)	($ 15,184)	($ 15,184)	註

註：本公司為重整集團組織架構，於 108 年 5 月 1 日由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec 公司依企業併購法讓與本公司。

【附件五】

一〇九年個體財務報告及會計師查核報告

股票代碼：6770

力晶積成電子製造股份有限公司

個體財務報告暨會計師查核報告

民國 109 及 108 年度

地址：新竹科學工業園區新竹市力行一路18號

電話：(03)579-5000

§目　　錄§

項目	頁次	財務報告附註編號
一、封　　面	1	-
二、目　　錄	2	-
三、會計師查核報告	3～6	-
四、個體資產負債表	7	-
五、個體綜合損益表	8～9	-
六、個體權益變動表	10	-
七、個體現金流量表	11～12	-
八、個體財務報告附註		
(一) 公司沿革	13	一
(二) 通過財務報告之日期及程序	13	二
(三) 新發布及修訂準則及解釋之適用	14～16	三
(四) 重大會計政策之彙總說明	16～28	四
(五) 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	28～29	五
(六) 重要會計項目之說明	29～61	六～二六
(七) 關係人交易	61～66	二七
(八) 質抵押之資產	66	二八
(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	66～67	二九
(十) 其　　他	-	-
(十一) 重大之災害損失	-	-
(十二) 重大之期後事項	-	-
(十三) 具重大影響之外幣資產及負債資訊	67	三十
(十四)附註揭露事項		
1. 重大交易事項相關資訊	67～71	三一
2. 轉投資事業相關資訊	67～71	三一
3. 大陸投資資訊	68	三一
4. 主要股東資訊	68、72	三一
(十五) 部門資訊	-	-
九、重要會計項目明細表	73～86	-

會計師查核報告

力晶積成電子製造股份有限公司　公鑒：

查核意見

力晶積成電子製造股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達力晶積成電子製造股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與力晶積成電子製造股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對力晶積成電子製造股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對力晶積成電子製造股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之真實性

由於收入認列具有顯著風險。本會計師認為力晶積成電子製造股份有限公司銷貨收入之交易存有真實性風險，故於本年度將主要銷售客戶之收入真實性認定為關鍵查核事項。

本會計師對此之查核程序包括：

1. 瞭解及測試收入認列之主要內部控制設計及執行之有效性。
2. 抽核並檢視銷售客戶其背景資料之真實性，並瞭解對其授信條件之合理性。
3. 針對銷貨收入選取樣本抽核，檢視經交易對象確認之訂單、出貨單及發票等文件，以確認銷貨收入真實性，並核對銷貨對象及現金收款對象是否異常。
4. 複核銷貨收入是否有重大異常期後銷貨退回及折讓之情事，以確認收入認列之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估力晶積成電子製造股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算力晶積成電子製造股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力晶積成電子製造股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實

表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對力晶積成電子製造股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使力晶積成電子製造股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致力晶積成電子製造股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於力晶積成電子製造股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成力晶積成電子製造股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對力晶積成電子製造股份有限公司民國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

強調事項

如財務報告附註一及十所述，力晶積成電子製造股份有限公司於民國 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶科技股份有限公司全部或主要之相關營業，並由力晶積成電子製造股份有限公司發行新股予母公司力晶科技股份有限公司做為收購之對價，及由母公司力晶科技股份有限公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.讓與力晶積成電子製造股份有限公司；與民國 108 年 4 月 1 日由力晶積成電子製造股份有限公司將持股 100%之富碩投資股份有限公司及 Sprout International Limited 全數出售予母公司力晶科技股份有限公司。前述交易係屬共同控制下之組織重組，是以應追溯視為自始取得或除列，並重編比較期間之個體財務報告。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　黃　裕　峰　　會計師　鍾　鳴　遠

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

中　華　民　國　110　年　3　月　9　日

力[illegible]公司

民[illegible]31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	109 年 12 月 31 日 金額	%	108 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二六）	$ 6,229,961	8	$ 3,977,560	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二六）	6,798	-	4,372	-
1170	應收帳款－非關係人淨額（附註四、八及二六）	5,981,210	8	5,344,970	7
1180	應收帳款－關係人淨額（附註四、八、二六及二七）	253,494	-	49,914	-
1200	其他應收款（附註四及二六）	240,167	-	453,449	1
130X	存貨（附註四、九及二七）	7,818,611	10	6,385,497	9
1410	預付款項	376,061	-	660,413	1
1476	其他金融資產－流動（附註四、六、二六及二八）	567,931	1	536,531	1
1479	其他流動資產－其他	57,255	-	192,217	-
11XX	流動資產總計	21,531,488	27	17,604,923	24
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一、十四、二四、二七及二八）	47,213,504	60	47,358,384	65
1755	使用權資產（附註四、五、十二及二七）	7,182,770	9	4,393,945	6
1780	無形資產（附註四及十三）	256,695	1	241,728	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	1,026,371	1	620,586	1
1915	預付設備款（附註二四）	90,063	-	1,540,275	2
1920	存出保證金（附註四、二六及二七）	5,606	-	7,077	-
1980	其他金融資產－非流動（附註四、六、二六及二八）	1,325,000	2	1,360,000	2
1990	其他非流動資產－其他（附註二四）	79,159	-	51,152	-
15XX	非流動資產總計	57,179,168	73	55,573,147	76
1XXX	資產總計	$ 78,710,656	100	$ 73,178,070	100

代碼	負債及權益	109 年 12 月 31 日 金額	%	108 年 12 月 31 日 金額	%
	流動負債				
2130	合約負債－流動（附註四、十九及二七）	$ 701,243	1	$ 926,359	1
2170	應付帳款－非關係人（附註二六）	2,641,535	3	2,583,447	4
2213	應付設備款（附註二四及二六）	1,574,291	2	1,797,230	2
2219	其他應付款（附註十五、二六及二七）	3,930,132	5	3,489,677	5
2280	租賃負債－流動（附註四、五、十二、二四、二六及二七）	354,050	1	215,566	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十四、二四、二六及二八）	7,065,983	9	5,512,049	8
2399	其他流動負債－其他（附註十六、二四及二六）	1,089,219	1	1,078,872	1
21XX	流動負債總計	17,356,453	22	15,603,200	21
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十四、二四、二六、二七及二八）	16,746,018	21	21,163,213	29
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	2,008,828	3	620,586	1
2580	租賃負債－非流動（附註四、五、十二、二四、二六及二七）	6,659,024	8	4,083,303	6
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	1,401,939	2	1,444,727	2
2645	存入保證金（附註二四及二六）	1,242,461	2	329,221	-
2650	採用權益法之投資貸餘（附註四及十）	78,244	-	57,439	-
25XX	非流動負債總計	28,136,514	36	27,698,489	38
2XXX	負債總計	45,492,967	58	43,301,689	59
	屬於本公司業主之權益（附註四及十八）				
3110	普通股股本	31,051,965	39	31,051,965	43
3200	資本公積	403,616	1	181,927	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	66,806	-	238,155	-
3350	未分配盈餘	1,695,690	2	(1,595,372)	(2)
3300	保留盈餘總計	1,762,496	2	(1,357,217)	(2)
3400	其他權益	(380)	-	(294)	-
3500	庫藏股票	(8)	-	-	-
31XX	本公司業主之權益總計	33,217,689	42	29,876,381	41
3XXX	權益總計	33,217,689	42	29,876,381	41
	負債及權益總計	$ 78,710,656	100	$ 73,178,070	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘（虧損）為元

代碼		109年度 金額	109年度 %	108年度 金額	108年度 %
4100	營業收入淨額（附註四、十九及二七）	$ 45,684,615	100	$ 35,897,121	100
5110	營業成本（附註四、九、二十及二七）	34,692,204	76	32,896,453	92
5900	營業毛利	10,992,411	24	3,000,668	8
	營業費用（附註二十及二七）				
6100	推銷費用	335,218	1	300,790	1
6200	管理費用	1,731,496	4	1,898,543	5
6300	研究發展費用	3,398,980	7	3,061,315	9
6000	營業費用合計	5,465,694	12	5,260,648	15
6500	其他收益及費損淨額（附註二十及二七）	211,550	-	172,015	1
6900	營業淨利（損）	5,738,267	12	(2,087,965)	(6)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二十）	27,972	-	62,531	-
7020	其他利益及損失（附註二十）	(283,526)	(1)	(64,025)	-
7050	財務成本（附註四、十四、二十及二七）	(668,196)	(1)	(513,094)	(2)
7060	採用權益法認列之子公司損益份額（附註四及十）	(20,719)	-	(15,184)	-
7000	營業外收入及支出合計	(944,469)	(2)	(529,772)	(2)
7900	稅前淨利（損）	4,793,798	10	(2,617,737)	(8)
7950	所得稅費用（附註四、五及二一）	(987,321)	(2)	(25,447)	-
8200	本年度淨利（損）	3,806,477	8	(2,643,184)	(8)

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		109年度 金　額	109年度 %	108年度 金　額	108年度 %
	其他綜合損益（附註四、十七及十八）				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	($ 86,764)	-	($ 110,925)	-
	後續可能重分類至損益之項目：				
8380	採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額	(86)	-	(294)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(86,850)	-	(111,219)	-
8500	本年度綜合損益總額	$ 3,719,627	8	($ 2,754,403)	(8)
	淨利（損）歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 3,806,477	8	($ 1,480,370)	(4)
8615	共同控制下前手權益	-	-	(1,162,814)	(3)
8600		$ 3,806,477	8	($ 2,643,184)	(7)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 3,719,627	8	($ 1,551,814)	(5)
8715	共同控制下前手權益	-	-	(1,162,814)	(3)
8715	共同控制下後手權益	-	-	(39,775)	-
8700		$ 3,719,627	8	($ 2,754,403)	(8)
	每股盈餘（虧損）（附註二二）				
9710	基　本	$ 1.23		($ 0.94)	
9810	稀　釋	$ 1.21		($ 0.94)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃崇仁　經理人：謝再居　會計主管：邱垂源

[illegible]公司

民[illegible]年12月31日

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益（附註十八）														
										其他權益項目						
		股本		資本公積				保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	庫藏股票	總計	非控制權益	控制權益	權益總計
		股數（仟股）	金額	股票發行溢價	受贈資產	員工認股權	合計	法定盈餘公積	未分配盈餘							
A1	108年1月1日餘額	358,667	$ 3,586,674	$ 89,200	$ -	$ -	$ 89,200	$ 139,562	$ 1,050,937	($ 4,316)	$ 356	$ -	$ 4,862,413	$ 25,295,906	($ 197,512)	$ 29,960,807
	盈餘指撥及分配															
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	98,593	(98,593)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(95,234)	-	-	-	(95,234)	-	-	(95,234)
B9	本公司股東股票股利	85,711	857,109	-	-	-	-	-	(857,109)	-	-	-	-	-	-	-
D1	108年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	(1,480,370)	-	-	-	(1,480,370)	(1,162,814)	-	(2,643,184)
D3	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(110,925)	(294)	39,775	-	(71,444)	-	(39,775)	(111,219)
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	(1,591,295)	(294)	39,775	-	(1,551,814)	(1,162,814)	(39,775)	(2,754,403)
N1	股份基礎給付交易	-	-	11,247	-	-	11,247	-	-	-	-	-	11,247	-	-	11,247
E1	現金增資	400,000	4,000,000	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	4,040,000	-	-	4,040,000
H3	組織重組	2,260,838	22,608,182	41,480	-	-	41,480	-	(4,078)	4,316	(40,131)	-	22,609,769	(24,593,842)	237,287	(1,746,786)
T1	將子權益於本年度分配員工酬勞轉列股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,750	-	460,750
Z1	108年12月31日餘額	3,105,196	31,051,965	181,927	-	-	181,927	238,155	(1,595,372)	(294)	-	-	29,876,381	-	-	29,876,381
	盈餘指撥及分配															
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	66,806	(66,806)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(600,000)	-	-	-	(600,000)	-	-	(600,000)
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	(238,155)	238,155	-	-	-	-	-	-	-
C3	因受領財務產生者	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	(8)	-	-	-	-
D1	109年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	3,806,477	-	-	-	3,806,477	-	-	3,806,477
D3	109年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(86,764)	(86)	-	-	(86,850)	-	-	(86,850)
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	3,719,713	(86)	-	-	3,719,627	-	-	3,719,627
N1	股份基礎給付交易	-	-	-	-	221,681	221,681	-	-	-	-	-	221,681	-	-	221,681
Z1	109年12月31日餘額	3,105,196	$ 31,051,965	$ 181,927	$ 8	$ 221,681	$ 403,616	$ 66,806	$ 1,695,690	($ 380)	$ -	($ 8)	$ 33,217,689	$ -	$ -	$ 33,217,689

後附之附註係本個別財務報告之一部分。

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　會計主管：鄭皇源

力晶積成電子製造股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		109 年度	108 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	$ 4,793,798	($ 2,617,737)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	5,851,651	4,847,723
A20200	攤銷費用	126,621	331,790
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨（利益）損失	(2,426)	2,698
A20900	財務成本	668,196	513,094
A21200	利息收入	(27,972)	(62,531)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	221,681	11,247
A22300	採用權益法認列之子公司損失之份額	20,719	15,184
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(28,749)	(950)
A23700	存貨呆滯及跌價（回升利益）損失	(481,318)	350,932
A24100	外幣兌換淨利益	(306,021)	(70,406)
A29900	退款負債（迴轉）提列數	(1,000)	31,723
A29900	押金設算利息收入	50	54
A29900	押金設算利息費用	-	(1)
A29900	其　他	(24)	(1,401)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款（含關係人）	(839,820)	899,396
A31180	其他應收款	281,632	36,444
A31200	存　貨	(951,795)	7,346
A31230	預付款項	303,829	44,225
A31240	其他流動資產	134,962	(160,097)
A32125	合約負債	(135,620)	(140,971)
A32150	應付帳款（含關係人）	58,088	(432,539)
A32180	其他應付款	367,782	(1,850,908)
A32240	淨確定福利負債－非流動	(129,552)	(120,256)
A32230	其他流動負債	(320,716)	422,394
A33000	營運產生之淨現金流入	9,603,996	2,056,453

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		109 年度	108 年度
A33100	收取之利息	$ 29,606	$ 59,780
A33500	退還（支付）之所得稅	4,220	(36,266)
AAAA	營業活動之淨現金流入	9,637,822	2,079,967
	投資活動之現金流量		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,305,046)	(12,166,035)
B02800	處分不動產、廠房及設備	15,284	56,666
B03700	存出保證金增加	(360)	(198)
B03800	存出保證金減少	1,831	873
B04500	取得無形資產	(71,298)	(35,232)
B06500	其他金融資產減少（增加）	3,600	(492,139)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,355,989)	(12,636,065)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	300,000	2,250,000
C00200	短期借款減少	(300,000)	(2,939,435)
C01600	舉借長期借款	1,919,000	12,277,800
C01700	償還長期借款	(5,539,868)	(5,676,344)
C03000	存入保證金增加	1,241,570	210,311
C03100	存入保證金減少	(114,302)	(72,983)
C04020	租賃負債本金償還	(264,680)	(98,666)
C04500	發放現金股利	(600,000)	(95,234)
C04600	現金增資	-	4,040,000
C05600	支付之利息	(592,042)	(407,151)
C09900	其他預付款項	(79,110)	-
C09900	共同控制下前手權益減少數	-	(1,920,633)
CCCC	籌資活動之淨現金流（出）入	(4,029,432)	7,567,665
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）數	2,252,401	(2,988,433)
E00100	年初現金及約當現金餘額	3,977,560	6,965,993
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 6,229,961	$ 3,977,560

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃崇仁　經理人：謝再居　會計主管：邱垂源

力晶積成電子製造股份有限公司

個體財務報表附註

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（除另註明外，金額以新台幣仟元為單位）

一、公司沿革

力晶積成電子製造股份有限公司（以下稱「本公司」），係由力晶科技股份有限公司（以下稱「力晶公司」）分割設立，以 97 年 4 月 1 日為分割基準日，並經科學工業園區管理局核准設立。主要營業項目為從事各式積體電路之研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工及銷售。

力晶公司為重整集團組織架構，進行以下組織重整：

(一) 本公司於 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業，並由本公司發行新股予力晶公司作為收購之對價；及由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.（以下稱「Global Powertec 公司」）讓與本公司；

(二) 108 年 4 月 1 日由本公司將持股 100%之富碩投資股份有限公司（以下稱「富碩公司」）及 Sprout International Limited（以下稱「Sprout 公司」）全數出售予力晶公司。

力晶公司於 109 年 6 月辦理減資，將所持有之本公司股票抵充應退還之減資股款，致力晶公司對本公司持股比例由 87.12%降至 26.82%，對本公司具有重大影響力。

本公司股票自 109 年 12 月起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。

本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告於 110 年 3 月 9 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 首次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRSs」）

除下列說明外，適用修正後之金管會認可並發布生效之 IFRSs 將不致造成本公司會計政策之重大變動：

1. 國際會計準則第 1 號及國際會計準則第 8 號之修正「重大性之定義」

本公司自 109 年 1 月 1 日開始適用該修正，改以「可被合理預期將影響使用者」作為重大性之門檻，並調整個體財務報告之揭露，刪除可能使重大資訊模糊化之不重大資訊。

(二) 110 年適用之金管會認可之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會（IASB）發布之生效日
國際財務報導準則第 4 號之修正「適用國際財務報導準則第 9 號之暫時豁免之展延」	發布日起生效
國際財務報導準則第 9 號、國際會計準則第 39 號、國際財務報導準則第 7 號、國際財務報導準則第 4 號及國際財務報導準則第 16 號之修正「利率指標變革－第二階段」	2021 年 1 月 1 日以後開始之年度報導期間生效
國際財務報導準則第 16 號之修正「新型冠狀病毒肺炎相關租金減讓」	2020 年 6 月 1 日以後開始之年度報導期間生效

除上述影響外，截至本個體財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

(三) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRSs

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註 1)
「2018-2020 週期之年度改善」	2022 年 1 月 1 日（註 2）
國際財務報導準則第 3 號之修正「更新對觀念架構之索引」	2022 年 1 月 1 日（註 3）
國際財務報導準則第 10 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	未　　定

（接次頁）

（承前頁）

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB發布之生效日(註1)
國際財務報導準則第17號「保險合約」	2023年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正	2023年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債分類為流動或非流動」	2023年1月1日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	2023年1月1日（註6）
國際會計準則第8號之修正「會計估計之定義」	2023年1月1日（註7）
國際會計準則第16號之修正「不動產、廠房及設備：達到預定使用狀態前之價款」	2022年1月1日（註4）
國際會計準則第37號之修正「虧損性合約－履行合約之成本」	2022年1月1日（註5）

註1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。

註2：國際財務報導準則第9號之修正適用於2022年1月1日以後開始之年度報導期間所發生之金融負債之交換或條款修改；國際會計準則第41號「農業」之修正適用於2022年1月1日以後開始之年度報導期間之公允價值衡量；國際財務報導準則第1號「首次採用IFRSs」之修正係追溯適用於2022年1月1日以後開始之年度報導期間。

註3：收購日在年度報導期間開始於2022年1月1日以後之企業合併適用此項修正。

註4：於2021年1月1日（最早表達期間開始日）以後始達管理階層預期運作方式之必要地點及狀態之廠房、不動產及設備適用此項修正。

註5：於2022年1月1日尚未履行所有義務之合約適用此項修正。

註6：於2023年1月1日以後開始之年度報導期間推延適用此項修正。

註7：於2023年1月1日以後開始之年度報導期間所發生之會計估計變動及會計政策變動適用此項修正。

截至本個體財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估上述準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外，本個體財務報告係依歷史成本基礎編製。歷史成本通常依照取得資產所支付對價之公允價值決定。

公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級：

1. 第 1 等級輸入值：係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價（未經調整）。
2. 第 2 等級輸入值：係指除第 1 等級之報價外，資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）之可觀察輸入值。
3. 第 3 等級輸入值：係指資產或負債之不可觀察之輸入值。

本公司於編製個體財務報告時，對投資子公司採權益法處理。為使本個體財務報告之本年度損益、其他綜合損益及權益與本公司合併財務報告中歸屬於本公司業主之本年度損益、其他綜合損益及權益相同，個體基礎與合併基礎下若干會計處理差異係調整「採用權益法之投資」、「採用權益法之投資貸餘」、「採用權益法認列之子公司損益份額」、「採用權益法認列之子公司其他綜合損益份額」暨相關權益項目。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括：

1. 主要為交易目的而持有之資產；
2. 預期於資產負債表日後 12 個月內實現之資產；及

3. 現金及約當現金（但不包括於資產負債表日後逾12個月用以交換或清償負債而受到限制者）。

流動負債包括：

1. 主要為交易目的而持有之負債；
2. 於資產負債表日後12個月內到期清償之負債（即使於資產負債表日後至通過發布財務報告前已完成長期性之再融資或重新安排付款協議，亦屬流動負債），以及
3. 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少12個月之負債。

非屬上述流動資產或流動負債者，係分類為非流動資產或非流動負債。

(四) 外　　幣

本公司編製個體財務報告時，以本公司功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，依交易日匯率換算為功能性貨幣記錄。

外幣貨幣性項目於每一資產負債表日以收盤匯率換算。除為規避部分匯率風險而進行避險交易所產生之兌換差額外，因交割貨幣性項目或換算貨幣性項目產生之兌換差額，於發生當期認列於損益。

以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目係以決定公允價值當日之匯率換算，所產生之兌換差額列為當期損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益。

以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

於編製個體財務報告時，本公司國外營運機構（包含營運所在國家或使用之貨幣與本公司不同之子公司）之資產及負債以每一資產負債表日匯率換算為新台幣。收益及費損項目係以當期平均匯率換算，所產生之兌換差額列於其他綜合損益。

若本公司處分國外營運機構之所有權益，或處分國外營運機構之子公司部分權益但喪失控制，或處分國外營運機構之聯合協議或關聯企業後之保留權益係金融資產並按金融工具之會計政策處理，所有與該國外營運機構相關之累計兌換差額將重分類至損益。

若部分處分國外營運機構之子公司未導致喪失控制，係按比例將累計兌換差額併入權益交易計算，但不認列為損益。在其他任何部分處分國外營運機構之情況下，累計兌換差額則按處分比例重分類至損益。

(五) 存　　貨

存貨包括原料、在製品及製成品，存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。另固定製造費用應按生產設備之正常產能分攤，因產能較低或設備閒置導致之未分攤固定製造費用，應於發生當年度認列銷貨成本。

本公司之存貨平時按標準成本計價，結帳日再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。

(六) 投資子公司

本公司採用權益法處理對子公司之投資。

子公司係指本公司具有控制之個體。

權益法下，投資原始依成本認列，取得日後帳面金額係隨本公司所享有之子公司損益及其他綜合損益份額與利潤分配而增減。此外，針對本公司可享有子公司其他權益之變動係按持股比例認列。

當本公司對子公司所有權權益之變動未導致喪失控制者，係作為權益交易處理。投資帳面金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額，係直接認列為權益。

當本公司對子公司之損失份額等於或超過其在該子公司之權益（包括權益法下子公司之帳面金額及實質上屬於本公司對該子公司淨投資組成部分之其他長期權益）時，係繼續按持股比例認列損失。

取得成本超過本公司於取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額之數額列為商譽，該商譽係包含於該投資之帳面金額且不得攤銷；本公司於取得日所享有構成業務之子公司可辨認資產及負債淨公允價值份額超過取得成本之數額列為當期收益。

本公司評估減損時，係以財務報告整體考量現金產生單位並比較其可回收金額與帳面金額。嗣後若資產可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟資產於減損損失迴轉後之帳面金額，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列攤銷後之帳面金額。歸屬於商譽之減損損失不得於後續期間迴轉。

當喪失對子公司控制時，本公司係按喪失控制日之公允價值衡量其對前子公司之剩餘投資，剩餘投資之公允價值及任何處分價款與喪失控制當日之投資帳面金額之差額，列入當期損益。此外，於其他綜合損益中所認列與該子公司有關之所有金額，其會計處理係與本公司直接處分相關資產或負債所必須遵循之基礎相同。

本公司與子公司之順流交易未實現損益於個體財務報告予以銷除。本公司與子公司之逆流及側流交易所產生之損益，僅在與本公司對子公司權益無關之範圍內，認列於個體財務報告。

(七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本認列，後續以成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量。

建造中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損損失後之金額認列。成本包括專業服務費用及符合資本化條件之借款成本。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

不動產、廠房及設備於耐用年限內按直線基礎，對每一重大部分單獨提列折舊。本公司每一年度結束日對估計耐用年限、殘值及折舊方法進行檢視，並推延適用會計估計變動之影響。

不動產、廠房及設備除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於損益。

(八) 無形資產

1. 單獨取得

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損損失後之金額衡量。無形資產於耐用年限內按直線基礎進行攤銷，並且於每一年度結束日

對估計耐用年限、殘值及攤銷方法進行檢視。並推延適用會計估計變動之影響。非確定耐用年限無形資產係以成本減除累計減損損失列報。

2. 除　　列

無形資產除列時，淨處分價款與該資產帳面金額間之差額係認列於當期損益。

(九) 不動產、廠房及設備、使用權資產、無形資產及合約成本相關資產之減損

本公司於每一資產負債表日評估是否有任何跡象顯示不動產、廠房及設備、使用權資產、無形資產及合約成本相關資產可能已減損。若有任一減損跡象存在，則估計該資產之可回收金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，本公司估計該資產所屬現金產生單位之可回收金額。共用資產係依合理一致基礎分攤至個別現金產生單位。

針對非確定耐用年限及尚未可供使用之無形資產，至少每年及有減損跡象時進行減損測試。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值之較高者。個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於其帳面金額時，將該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失係認列於損益。

適用國際財務報導準則第 15 號之客戶合約，因客戶合約所認列之存貨、不動產、廠房及設備及無形資產先依存貨減損規定及上述規定認列減損，次依合約成本相關資產之帳面金額超過提供相關商品或勞務預期可收取之對價剩餘金額扣除直接相關成本後之金額認列為減損損失，續將合約成本相關資產之帳面金額計入所屬現金產生單位，以進行現金產生單位之減損評估。

當減損損失於後續迴轉時，該資產、現金產生單位或合約成本相關資產之帳面金額調增至修訂後之可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產、現金產生單位或合約成本相關資產若未於以

前年度認列減損損失時所決定之帳面金額（減除攤銷或折舊）。減損損失之迴轉係認列於損益。

(十) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該工具合約條款之一方時認列於個體資產負債表。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

1. 金融資產

金融資產之慣例交易係採交易日會計認列及除列。

(1) 衡量種類

金融資產係分為透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資及按攤銷後成本衡量之金融資產。

A.透過損益按公允價值衡量之金融資產

透過損益按公允價值衡量之金融資產係強制透過損益按公允價值衡量之金融資產。其產生之利益或損失係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

B.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資

本公司於原始認列時，可作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資，指定透過其他綜合損益按公允價值衡量。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，其後續公允價值變動認列於其他綜合損益，並累計於其他權益中。於投資處分時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資之股利於本公司具收款之權利時認列於損益，除非該收

款之權利明顯代表部分投資成本之回收。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

C.按攤銷後成本衡量

現金及約當現金、債務工具投資、應收帳款（含關係人）、其他應收款項、受限制存款及存出保證金係按攤銷後成本衡量。

債務工具投資之合約條款為完全支付本金及流通在外本金金額之利息，且持有目的係以收取合約現金流量，則分類為按攤銷後成本衡量之金融資產。

按攤銷後成本衡量之各類金融資產於原始認列後，係以有效利息法決定之帳面價值減除任何減損損失之攤銷後成本衡量。

約當現金包括自取得日起 3 個月內、高度流動性、可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之定期存款，係用於滿足短期現金承諾。

(2) 金融資產及合約資產之減損

本公司於每一資產負債表日按預期信用損失評估按攤銷後成本衡量之金融資產（含應收帳款）。

應收帳款按存續期間預期信用損失認列備抵損失。其他金融資產係先評估自原始認列後信用風險是否顯著增加，若未顯著增加，則按 12 個月預期信用損失認列備抵損失，若已顯著增加，則按存續期間預期信用損失認列備抵損失。

所有金融資產之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。

(3) 金融資產之除列

本公司僅於對來自金融資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

於一按攤銷後成本衡量之金融資產整體除列時，其帳面金額與所收取對價間之差額係認列於損益。於一透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資整體除列時，累積損益直接移轉至保留盈餘，並不重分類為損益。

2. 權益工具

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

再取回本公司本身之權益工具係於權益項下認列與減除。購買、出售、發行或註銷本公司本身之權益工具不認列於損益。

3. 金融負債

(1) 後續衡量

除透過損益按公允價值衡量之金融負債外，所有金融負債係以有效利息法按攤銷後成本衡量：

<u>透過損益按公允價值衡量之金融負債</u>

透過損益按公允價值衡量之金融負債包含持有供交易之金融負債。

持有供交易之金融負債係按公允價值衡量，其再衡量產生之利益或損失（包含該金融負債所支付之任何股利或利息）係認列於損益。公允價值之決定方式請參閱附註二六。

(2) 金融負債之除列

除列金融負債時，其帳面金額與所支付對價（包含任何所移轉之非現金資產或承擔之負債）間之差額認列為損益。

4. 衍生工具

本公司簽訂之衍生工具包括遠期外匯合約，用以管理本公司之匯率風險。

衍生工具於簽訂衍生工具合約時，原始以公允價值認列，後續於資產負債表日按公允價值再衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。當衍生工具之公允價值為正值時，列為金融資產；公允價值為負值時，列為金融負債。

(十一) 收入認列

本公司於客戶合約辨認履約義務後，並於滿足各履約義務時認列收入。

商品銷貨收入

商品銷貨收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。本公司基於歷史經驗及考量不同之合約條件，以估計可能發生之銷貨退回及折讓，據以認列退款負債。

商品銷貨收入來自矽晶圓產品之銷售。產品於出貨時或運抵客戶指定地點時認列收入及應收帳款。銷售之預收款項，於商品認列收入前係認列為合約負債。

(十二) 租　　賃

本公司於合約成立日評估合約是否係屬（或包含）租賃。

1. 本公司為出租人

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人，則將其分類為融資租賃。所有其他租賃則分類為營業租賃。

本公司於轉租使用權資產時，係以使用權資產（而非標的資產）判斷轉租之分類。惟若主租賃係本公司適用認列豁免之短期租賃時，該轉租分類為營業租賃。

營業租賃下，減除租賃誘因後之租賃給付係按直線基礎於相關租賃期間內認列為收益。因取得營業租賃所發生之原始直接成本，係加計至標的資產之帳面金額，並按直線基礎於租賃

期間內認列為費用。與承租人進行之租賃協商係於租賃修改生效日起按新租賃處理。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為收益。

2. 本公司為承租人

除適用認列豁免之低價值標的資產租賃及短期租賃之租賃給付係按直線基礎於租賃期間內認列為費用，其他租賃皆於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債。

使用權資產原始按成本（包含租賃負債之原始衡量金額、租賃開始日前支付之租賃給付減除收取之租賃誘因、原始直接成本及復原標的資產之估計成本）衡量，後續按成本減除累計折舊及累計減損損失後之金額衡量，並調整租賃負債之再衡量數。使用權資產係單獨表達於個體資產負債表。

使用權資產採直線基礎自租賃開始日起至耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者提列折舊。若租賃期間屆滿時將取得標的資產所有權，或若使用權資產之成本反映購買選擇權之行使，則自租賃開始日起至標的資產耐用年限屆滿時提列折舊。

租賃負債原始按租賃給付之現值衡量。若租賃隱含利率容易確定，租賃給付使用該利率折現。若該利率並非容易確定，則使用承租人增額借款利率。

後續，租賃負債採有效利息法按攤銷後成本基礎衡量，且利息費用係於租賃期間分攤。若租賃期間或用於決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動，本公司再衡量租賃負債，並相對調整使用權資產，惟若使用權資產之帳面金額已減至零，則剩餘之再衡量金額認列於損益中。對於不以單獨租賃處理之租賃修改，因減少租賃範圍之租賃負債再衡量係調減使用權資產，並認列租賃部分或全面終止之損益；因其他修改之租賃負債再衡量係調整使用權資產。租賃負債係單獨表達於個體資產負債表。

租賃協議中非取決於指數或費率之變動租金於發生當期認列為費用。

(十三) 借款成本

直接可歸屬於取得及建造符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產達到預定使用狀態之幾乎所有必要活動已完成為止。

特定借款如於符合要件之資本支出發生前進行暫時投資而賺取之投資收入，係自符合資本化條件之借款成本中減除。

除上述外，所有其他借款成本係於發生當期認列為損益。

(十四) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利相關負債係以換取員工服務而預期支付之非折現金額衡量。

2. 退職後福利

確定提撥退休計畫之退休金係於員工提供服務之期間，將應提撥之退休金數額認列為費用。

確定福利退休計畫之確定福利成本（含服務成本、淨利息及再衡量數）係採預計單位福利法精算。服務成本（含當期服務成本及前期服務成本）及淨確定福利負債（資產）淨利息於發生時、計畫修正或縮減時認列為員工福利費用。再衡量數（含精算損益、資產上限影響數之變動及扣除利息後之計畫資產報酬）於發生時認列於其他綜合損益並列入保留盈餘，後續期間不重分類至損益。

淨確定福利負債係確定福利退休計畫之提撥短絀。

(十五) 股份基礎給付協議

給與員工之員工認股權

員工認股權係按給與日權益工具之公允價值及預期既得之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積。若其於給與日立即既得，係於給與日全數認列費用。本公司辦理現金增資保留員工認購，係確認員工認購股數之日為給與日。

本公司於每一資產負債表日修正預期既得之員工認股權估計數量。若有修正原估計數量，其影響數係認列為損益，使累計費用反映修正之估計數，並相對調整資本公積。

(十六) 所得稅

所得稅費用係當期應付所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當期所得稅

依中華民國所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵所得稅，係於股東會決議年度認列。

以前年度應付所得稅之調整，列入當期所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算。

遞延所得稅負債一般係就所有應課稅暫時性差異予以認列，而遞延所得稅資產則於很有可能有課稅所得以供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

與投資子公司、關聯企業及合資權益相關之應課稅暫時性差異皆認列遞延所得稅負債，惟本公司若可控制暫時性差異迴轉之時點，且該暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者除外。與此類投資及權益有關之可減除暫時性差異，僅於其很有可能有足夠課稅所得用以實現暫時性差異之利益，且於可預見之未來預期將迴轉的範圍內，予以認列遞延所得稅資產。

遞延所得稅資產之帳面金額於每一資產負債表日予以重新檢視，並針對已不再很有可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調減帳面金額。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於每一資產負債表日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者，調增帳面金額。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當期之稅率衡量，該稅率係以資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映本

公司於資產負債表日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅後果。

3. 當期及遞延所得稅

當期及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當期及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用會計政策時，對於不易自其他來源取得相關資訊者，管理階層必須基於歷史經驗及其他攸關之因素作出相關之判斷、估計及假設。實際結果可能與估計有所不同。

本公司將新型冠狀病毒肺炎疫情造成之經濟影響納入重大會計估計之考量，管理階層將對估計與基本假設持續檢視。若估計之修正僅影響當期，則於修正當期認列；若會計估計之修正同時影響當期及未來期間，則於修正當期及未來期間認列。

重大會計判斷

(一) 租賃期間

決定所承租資產之租賃期間時，本公司考量將產生經濟誘因以行使（或不行使）選擇權之所有攸關事實及情況，包括自租賃開始日至選擇權行使日間所有事實及情況之預期變動。考量主要因素包括選擇權所涵蓋期間之合約條款及條件、於合約期間進行之重大租賃權益改良及標的資產對承租人營運之重要性等。於本公司控制範圍內重大事項或情況重大改變發生時，重評估租賃期間。

估計及假設不確定性之主要來源

(一) 所得稅

遞延所得稅資產係於未來很有可能有足夠之課稅所得供可減除暫時性差異使用時方予以認列。評估遞延所得稅資產之可實現性時，必須涉及管理階層之重大會計判斷及估計，包含預期未來銷貨收入成長及利潤率、可使用之所得稅抵減及稅務規畫等假設。任何關於全球經濟環境、產業環境的變遷及法令的改變，均可能引起遞延所得稅資產之重大調整。

(二) 承租人增額借款利率

決定租賃給付折現所使用之承租人增額借款利率，係以相當存續期間及幣別之無風險利率做為參考利率，並將所估計之承租人信用風險貼水及租賃特定調整（例如，資產特性及附有擔保等因素）納入考量。

六、現金及約當現金

	109年12月31日	108年12月31日
活期存款	$ 3,457,905	$ 1,850,085
支票存款	19,044	15,780
約當現金		
銀行定期存款	4,645,943	3,708,226
附買回債券	-	300,000
	8,122,892	5,874,091
受限制存款（帳列其他金融資產）	(1,892,931)	(1,896,531)
	$ 6,229,961	$ 3,977,560

銀行存款及附買回債券於資產負債表日之市場利率區間如下：

	109年12月31日	108年12月31日
銀行存款	0%~2.40%	0%~2.60%
附買回債券	-	0.53%

七、透過損益按公允價值衡量之金融資產

	109年12月31日	108年12月31日
金融資產－流動		
強制透過損益按公允價值衡量		
衍生工具		
－遠期外匯合約	$ 6,798	$ 4,372

於資產負債表日未適用避險會計且尚未到期之遠期外匯合約如下：

	幣別	到期期間	合約金額（仟元）
109 年 12 月 31 日			
賣出遠期外匯	美金兌日圓	110.01.07~110.02.08	USD 22,553/ JPY 2,350,000
108 年 12 月 31 日			
賣出遠期外匯	美金兌新台幣	109.01.03	USD 5,000/ NTD 152,300
	美金兌日圓	109.01.06~109.01.30	USD 13,736/ JPY 1,500,000

本公司從事遠期外匯交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。

八、應收帳款

	109年12月31日	108年12月31日
按攤銷後成本衡量		
應收帳款－非關係人	$5,981,210	$5,344,970
減：備抵損失	-	-
	5,981,210	5,344,970
應收帳款－關係人	253,494	49,914
減：備抵損失	-	-
	253,494	49,914
應收帳款淨額	$6,234,704	$5,394,884

本公司對商品銷售之平均授信期間為月結30～60天，應收帳款不予計息。為減輕信用風險，本公司管理階層依公司相關之政策、程序及內部控制，指派專責團隊負責授信作業及其他監控程序，以確保逾期應收帳款之回收已採取適當行動，並按權責由管理階層負責授信額度之決定及授信核准。此外，本公司會定期逐一複核應收帳款之可回收金額以確保無法回收之應收帳款項已提列適當減損損失。

本公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算，其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量GDP預測及產業展望。

若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且本公司無法合理預期可回收金額，例如交易對方正進行清算或債款已逾期，本公司直接沖銷相關應收帳款，惟仍會持續追索活動，因追索回收之金額則認列於損益。

本公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下：

109年12月31日

	未逾期	逾期1～30天	逾期31～60天	逾期61～90天	逾期超過90天	合計
總帳面金額	$6,101,702	$ 125,424	$ 7,578	$ -	$ -	$6,234,704
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$6,101,702	$ 125,424	$ 7,578	$ -	$ -	$6,234,704

108年12月31日

	未逾期	逾期1～30天	逾期31～60天	逾期61～90天	逾期超過90天	合計
總帳面金額	$4,620,136	$ 768,649	$ 6,099	$ -	$ -	$5,394,884
備抵損失（存續期間預期信用損失）	-	-	-	-	-	-
攤銷後成本	$4,620,136	$ 768,649	$ 6,099	$ -	$ -	$5,394,884

九、存　　貨

	109年12月31日	108年12月31日
製成品	$ 598,004	$ 542,260
在製品	4,443,891	3,842,467
原　料	2,776,716	2,000,770
	$ 7,818,611	$ 6,385,497

109 及 108 年度與存貨相關之銷貨成本分別為 34,692,204 仟元及 32,896,453 仟元。

109 及 108 年度之銷貨成本包括實際產能使用較低所導致之未分攤固定製造費用分別為 252,287 仟元及 3,064,643 仟元，109 年認列存貨呆滯及跌價回升利益 481,318 仟元，主係因產品價格回升所致；108 年提列存貨呆滯及跌價損失 350,932 仟元。

十、採用權益法之投資貸餘

投資子公司

	109年12月31日	108年12月31日
非上市（櫃）公司		
Global Powertec Co., Ltd.（Global Powertec 公司）	$ 78,244	$ 57,439

本公司於資產負債表日對子公司之所有權權益及表決權百分比如下：

	109年12月31日	108年12月31日
Global Powertec 公司	100%	100%

本公司為重整集團組織架構，於 108 年 4 月 1 日由本公司將持股 100%之富碩公司及 Sprout 公司全數出售予力晶公司；於 108 年 5 月 1 日由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec 公司依企業併購法讓與本公司。

上述子公司之業務性質，主要營業場所及公司註冊之國家資訊，請參閱附表三「被投資公司資訊、所在地區…等相關資訊」附表。

本公司 109 及 108 年度採用權益法之子公司之損益及其他綜合損益份額，係依據子公司同期間經會計師查核之財務報告認列。

十一、不動產、廠房及設備

自　　用

	109年12月31日	108年12月31日
自　　用	$ 47,213,504	$ 47,358,384

	109年12月31日	108年12月31日
房屋及建築	$ 4,189,877	$ 4,380,121
機器設備	33,930,415	31,651,873
研發設備	1,685,369	1,837,813
廠務設備	6,415,656	6,207,126
運輸設備	2,156	2,719
生財器具	88,518	80,465
其他設備	85,574	120,452
待驗設備及未完工程	815,939	3,077,815
	$ 47,213,504	$ 47,358,384

自　　用

	109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				
	年初餘額	增加	出售或報廢	科目移轉	年底餘額
成　本					
房屋及建築	$ 11,660,693	$ -	$ -	$ 30,411	$ 11,691,104
機器設備	207,574,333	-	(2,132,385)	6,513,819	211,955,767
研發設備	3,017,271	-	(23,644)	188,265	3,181,892
廠務設備	31,064,913	-	-	729,036	31,793,949
運輸設備	11,699	-	-	-	11,699
生財器具	631,797	-	(16,438)	52,029	667,388
其他設備	1,854,885	-	(1,530)	42,610	1,895,965
	255,815,591	$ -	($ 2,173,997)	$ 7,556,170	261,197,764
累計折舊					
房屋及建築	7,280,572	$ 220,655	$ -	$ -	7,501,227
機器設備	175,883,873	4,350,659	(2,067,901)	(179,412)	177,987,219
研發設備	1,179,458	155,836	(23,644)	184,873	1,496,523
廠務設備	24,857,787	526,724	-	(6,218)	25,378,293
運輸設備	8,980	563	-	-	9,543
生財器具	551,332	43,967	(16,438)	9	578,870
其他設備	1,734,433	76,740	(1,530)	748	1,810,391
	211,496,435	$ 5,375,144	($ 2,109,513)	$ -	214,762,066
累計減損					
機器設備	38,587	$ -	($ 454)	$ -	38,133
待驗設備及未完工程	3,077,815	$ 5,294,294	$ -	($ 7,556,170)	815,939
淨　額	$ 47,358,384				$ 47,213,504

	108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				
	年初餘額	增加	出售或報廢	科目移轉	年底餘額
成本					
房屋及建築	$ 11,527,161	$ -	$ -	$ 133,532	$ 11,660,693
機器設備	201,763,144	-	(4,145,292)	9,956,481	207,574,333
研發設備	2,064,558	-	(5,918)	958,631	3,017,271
廠務設備	29,605,077	-	(5,138)	1,464,974	31,064,913
運輸設備	10,239	-	-	1,460	11,699
生財器具	603,003	-	(8,336)	37,130	631,797
其他設備	1,783,576	-	(4,626)	75,935	1,854,885
	247,356,758	$ -	($ 4,169,310)	$ 12,628,143	255,815,591
累計折舊					
房屋及建築	7,062,740	$ 217,832	$ -	$ -	7,280,572
機器設備	176,361,044	3,804,839	(4,088,777)	(193,233)	175,883,873
研發設備	866,937	126,983	(5,918)	191,456	1,179,458
廠務設備	24,451,844	411,078	(5,135)	-	24,857,787
運輸設備	8,640	340	-	-	8,980
生財器具	522,699	36,969	(8,336)	-	551,332
其他設備	1,655,834	81,798	(4,626)	1,427	1,734,433
	210,929,738	$ 4,679,839	($ 4,112,792)	($ 350)	211,496,435
累計減損					
機器設備	38,587	$ -	$ -	$ -	38,587
待驗設備及未完工程	4,298,694	$ 11,407,264	$ -	($ 12,628,143)	3,077,815
淨額	$ 40,687,127				$ 47,358,384

折舊費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

房屋及建築	21 至 40 年
機器設備	1.5 至 19 年
研發設備	1.5 至 19 年
廠務設備	6 至 30 年
運輸設備	6 年
生財器具	4 年
其他設備	4 年

本公司設定質押作為借款擔保之不動產、廠房及設備金額，請參閱附註十四及二八。

十二、租賃協議

(一) 使用權資產

	109年12月31日	108年12月31日
使用權資產帳面金額		
土地	$ 2,087,674	$ 1,523,791
建築物	138,400	149,983
機器設備	4,941,786	2,696,447
運輸設備	14,910	23,724
	$ 7,182,770	$ 4,393,945

	109年度	108年度
使用權資產之增添	$ 3,277,223	$ 2,768,430
使用權資產之折舊費用		
土　　地	$ 78,538	$ 70,872
建 築 物	31,975	32,236
機器設備	354,023	55,120
運輸設備	11,971	9,656
	$ 476,507	$ 167,884

(二) 租賃負債

	109年12月31日	108年12月31日
租賃負債帳面金額		
流　　動	$ 354,050	$ 215,566
非 流 動	$ 6,659,024	$ 4,083,303

租賃負債之折現率區間如下：

	109年12月31日	108年12月31日
土　　地	2.92%~3.74%	2.92%
建 築 物	1.79%~2.64%	1.79%~2.64%
機器設備	1.61%~4.58%	1.83%~4.58%
運輸設備	1.77%~1.97%	1.79%~1.97%

(三) 重要承租活動及條款

本公司承租若干土地及建築物做為廠房及辦公室使用，主要租賃期間為 20 年。位於中華民國之土地租賃約定每 2 年依公告地價調整租賃給付。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之土地及建築物並無優惠承購權。

本公司承租若干機器設備以供營業使用，租賃期間為 10 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之機器設備並無優惠承購權。

本公司另以融資租賃方式承租若干機器設備，租賃期間為 4.5 年～6.2 年。於租賃期間屆滿時，該機器設備所有權自動移轉為本公司所有。本公司之融資租賃義務係以出租人保有租賃資產之所有權作為擔保。

本公司承租若干公務車以供營業使用，租賃期間為 3～4 年。於租賃期間終止時，本公司對所租賃之公務車並無優惠承購權。

(四) 其他租賃資訊

	109年度	108年度
短期租賃費用	$ 7,425	$ 11,367
租賃之現金流出總額(含使用權資產)	$410,010	$153,335

本公司選擇對符合短期租賃之場地、機器設備與公務車租賃適用認列之豁免，不對該等租賃認列相關使用權資產及租賃負債。

十三、無形資產

	109年12月31日	108年12月31日
技術移轉及授權費	$110,606	$ 55,876
專 利 權	117,507	136,454
電腦軟體設備及系統費	18,795	45,088
其 他	9,787	4,310
	$256,695	$241,728

	技術移轉及授權費	電腦軟體設備及系統費	專利權	其他	合計
成本					
109年1月1日餘額	$1,324,100	$ 68,303	$ 307,550	$ 8,967	$1,708,920
增添	118,507	3,638	12,000	7,443	141,588
本期攤提完畢	(1,324,100)	(19,266)	-	(1,294)	(1,344,660)
109年12月31日餘額	$ 118,507	$ 52,675	$ 319,550	$ 15,116	$ 505,848
累計攤銷					
109年1月1日餘額	$1,268,224	$ 23,215	$ 171,096	$ 4,657	$1,467,192
攤銷費用	63,777	29,931	30,947	1,966	126,621
本期攤提完畢	(1,324,100)	(19,266)	-	(1,294)	(1,344,660)
109年12月31日餘額	$ 7,901	$ 33,880	$ 202,043	$ 5,329	$ 249,153
108年12月31日及109年1月1日淨額	$ 55,876	$ 45,088	$ 136,454	$ 4,310	$ 241,728
109年12月31日淨額	$ 110,606	$ 18,795	$ 117,507	$ 9,787	$ 256,695
成本					
108年1月1日餘額	$1,324,100	$ 181,298	$ 307,550	$ 27,699	$1,840,647
增添	-	46,594	-	-	46,594
本期攤提完畢	-	(159,589)	-	(18,732)	(178,321)
108年12月31日餘額	$1,324,100	$ 68,303	$ 307,550	$ 8,967	$1,708,920
累計攤銷					
108年1月1日餘額	$1,003,404	$ 151,454	$ 140,750	$ 18,115	$1,313,723
攤銷費用	264,820	31,350	30,346	5,274	331,790
本期攤提完畢	-	(159,589)	-	(18,732)	(178,321)
108年12月31日餘額	$1,268,224	$ 23,215	$ 171,096	$ 4,657	$1,467,192
108年12月31日淨額	$ 55,876	$ 45,088	$ 136,454	$ 4,310	$ 241,728

攤銷費用係以直線基礎按下列耐用年數計提：

技術移轉及授權費	5 年
電腦軟體設備及系統費	2 年
專 利 權	5 至 15 年
其　　他	2 至 5 年

十四、借　　款

長期借款

	109年12月31日	108年12月31日
擔保借款		
－長期抵押聯合貸款(一)	$15,058,180	$20,064,077
－長期抵押聯合貸款(二)	4,199,384	3,941,600
－長期抵押聯合貸款(三)	2,779,137	1,279,285
－關係人借款（參閱附註二七）	735,000	-
－其　　他	865,300	865,300
小　　計	23,637,001	26,150,262
無擔保借款		
－銀行借款	175,000	525,000
	23,812,001	26,675,262
減：列為 1 年內到期部分	(7,065,983)	(5,512,049)
長期借款	$16,746,018	$21,163,213

力晶公司於 107 年 3 月 14 日簽署長期抵押聯合貸款(一)之授信合約、分別於 107 年 12 月 10 日、108 年 12 月 25 日及 109 年 5 月 29 日簽署第一次、第二次及第三次增補合約，授信額度變更為新臺幣 24,500,000 仟元。依聯貸合約約定按季還本，到期日為 112 年 12 月，109 年及 108 年 12 月 31 日有效利率 1.79%。主要承諾事項如下：

(一) 力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，將聯合授信合約下之權利義務，於收購讓與基準日（即 108 年 5 月 1 日）轉讓予本公司，並自基準日起，本授信案由本公司擔任借款人。

(二) 本公司需於額度管理銀行開立營運收支專戶該專戶之餘額應於每季末檢視當季累積存（匯）入金額不得低於新台幣 6,000,000 仟元或等值外幣。

(三) 本公司於本授信案期間，每年資本支出加計非資本支出及現金股利之支出限額，不得超逾前一年度之稅後淨利加計折舊並扣除特別保留份額。非資本支出，係指包括借款人對關係人或與關係企業之資

金融通或還款及與借款人本業相關之長、短期投資股票或股權支出。但借款人對關係人或與關係企業之資金融通或還款屬借新還舊者不在此限。前述支出限額，依第二次增補合約規定，109 年為一固定限額，自 110 年起則不得超逾前一期期末之稅後淨利減除重大無現金流量之收入，加計折舊並扣除特別保留份額。

(四) 本公司於本授信案期間，每季需提供經額度管理銀行同意之會計師就資本支出、支出限額及相關約定之查核或檢核報告予額度管理銀行。

(五) 於債務清償前，本公司之年度合併財務報表受有流動比率、負債比率及利息保障倍數之限制。本公司截至 109 年 12 月 31 日止之各項財務比率均符合合約規定。

長期抵押聯合貸款(二)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 114 年 1 月，截至 109 年及 108 年 12 月 31 日有效利率分別為 1.87%及 1.86%。另貸款合約規定，本公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有負債比率、流動比率及利息保障倍數等限制。本公司截至 109 年 12 月 31 日止之各項財務比率均符合合約規定。

長期抵押聯合貸款(三)依合約規定於每季償付不等之金額，到期日為 113 年 2 月，截至 109 年及 108 年 12 月 31 日有效利率分別為 1.87%及 1.86%。另貸款合約規定，本公司之年度財務報表於聯貸案存續期間債務全部清償前受有負債比率、流動比率及利息保障倍數等限制。本公司截至 109 年 12 月 31 日止之各項財務比率均符合合約規定。

為償還既有金融機構借款，並充實中長期營運資金及購置機器設備暨其附屬設備，本公司於 109 年 11 月與金融機構簽訂新台幣 29,300,000 仟元之聯合授信合約。截至 109 年 12 月 31 日止，前述授信額度尚未動用，惟上述授信合約已於 110 年 1 月 18 日動撥 15,059,605 仟元。

長期借款擔保之情形，請參閱附註二八。

力晶公司分別於106年9月及106年12月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約約定按季還本，到期日為109年9月至109年12月。

力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於108年4月簽署中長期授信增補合約，將授信合約下之債務、權利及義務，於收購讓與基準日（即108年5月1日）轉讓予本公司，並自基準日起，前述無擔保銀行中長期額度貸款由本公司擔任借款人。截至109年12月止，前述中長期借款已清償完畢。

本公司分別於108年5月及108年7月動撥無擔保銀行中長期額度貸款。依合約規定每半年還本，到期日為111年5月及110年7月，截至109年12月31日止，年利率分別為1.35%及1.32%。

關係人借款：本公司於109年3月與關係人簽訂設備買賣融資借款，依合約約定按季付息，相關款項於到期日111年4月付清，截至109年12月31日止，年利率為1.80%。關係人交易請參閱附註二七。擔保之情形請參閱附註二八。

其他借款：力晶公司於106年5月至10月與金士頓公司承作設備買賣融資借款，相關款項於到期日108年10月一次支付。依設備買賣融資需支付價款設算隱含利率約為2.78%至2.89%。力晶公司依企業併購法之收購讓與計畫，於收購讓與基準日（即108年5月1日）轉讓予本公司，並自基準日起，本融資借款由本公司擔任借款人。前述借款於108年9月簽署增補合約，對方約定於110年10月一次清償借款，截至109年12月31日止，年利率為1.80%。擔保之情形請參閱附註二八。

十五、其他應付款

	109年12月31日	108年12月31日
應付薪資及獎金	$1,365,086	$1,231,066
應付員工及董事酬勞	542,871	-
應付權利金	303,512	488,941
應付電費	193,478	188,870
應付利息	29,332	31,946
其　　他	1,495,853	1,548,854
	$3,930,132	$3,489,677

十六、其他流動負債

	109年12月31日	108年12月31日
存入保證金	$ 415,357	$ 161,647
退款負債	190,000	191,000
其　　他	483,862	726,225
	$1,089,219	$1,078,872

十七、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

本公司適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

(二) 確定福利計畫

本公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算。該等公司按員工每月薪資總額 2%提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額。該專戶係委託勞動部勞動基金運用局管理，該等公司並無影響投資管理策略之權利。

列入個體資產負債表之確定福利計畫金額列示如下：

	109年12月31日	108年12月31日
已提撥確定福利義務之現值	$2,712,605	$2,605,324
計畫資產公允價值	(1,190,134)	(1,040,191)
淨確定福利負債	$1,522,471	$1,565,133

淨確定福利負債變動如下：

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
108 年 1 月 1 日	$ 2,467,078	($ 892,586)	$ 1,574,492
當期服務成本	17,760	-	17,760
利息費用（收入）	14,696	(5,239)	9,457
認列於損益	32,456	(5,239)	27,217

（接次頁）

（承前頁）

	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
再衡量數			
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	$ -	($ 991)	($ 991)
精算損失－人口統計假設變動	3,943	-	3,943
精算損失－財務假設變動	115,082	-	115,082
精算損失－經驗調整	(7,109)	-	(7,109)
認列於其他綜合損益	111,916	(991)	110,925
雇主提撥	-	(72,834)	(72,834)
福利支付	(21,135)	6,989	(14,146)
認列人口併入影響數	15,009	(75,530)	(60,521)
108 年 12 月 31 日	2,605,324	(1,040,191)	1,565,133
當期服務成本	25,834	-	25,834
利息費用（收入）	19,355	(7,764)	11,591
認列於損益	45,189	(7,764)	37,425
再衡量數			
計畫資產報酬（除包含於淨利息之金額外）	-	(32,597)	(32,597)
精算損失－人口統計假設變動	1,463	-	1,463
精算損失－財務假設變動	105,881	-	105,881
精算損失－經驗調整	12,017	-	12,017
認列於其他綜合損益	119,361	(32,597)	86,764
雇主提撥	-	(125,517)	(125,517)
福利支付	(57,269)	15,935	(41,334)
109 年 12 月 31 日	$ 2,712,605	($ 1,190,134)	$ 1,522,471

本公司因「勞動基準法」之退休金制度暴露於下列風險：

1. 投資風險：勞動部勞動基金運用局透過自行運用及委託經營方式，將勞工退休基金分別投資於國內（外）權益證券與債務證券及銀行存款等標的，惟本公司之計畫資產得分配金額係以不

低於當地銀行 2 年定期存款利率。如有低於該利率之情形，由國庫補足。

2. 利率風險：政府公債之利率下降將使確定福利義務現值增加，惟計畫資產之債務投資報酬亦會隨之增加，兩者對淨確定福利負債之影響具有部分抵銷之效果。

3. 薪資風險：確定福利義務現值之計算係參考計畫成員之未來薪資。因此計畫成員薪資之增加將使確定福利義務現值增加。

本公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算，衡量日之重大假設如下：

	109年12月31日	108年12月31日
折 現 率	0.40%	0.75%
薪資預期增加率	4.20%	4.25%
離 職 率	0.61%	0.71%

若重大精算假設分別發生合理可能之變動，在所有其他假設維持不變之情況下，將使確定福利義務現值增加（減少）之金額如下：

	109年12月31日	108年12月31日
折 現 率		
增加 0.25%	($ 87,916)	($ 87,141)
增加 0.10%	($ 35,627)	
減少 0.25%	$ 91,850	$ 91,170
減少 0.10%	$ 36,257	
薪資預期增加率		
增加 0.25%	$ 86,317	$ 85,929
減少 0.25%	($ 83,166)	($ 82,667)
離 職 率		
離職率 110%	($ 849)	($ 1,411)
離職率 90%	$ 851	$ 1,415

由於精算假設可能彼此相關，僅單一假設變動之可能性不大，故上述敏感度分析可能無法反映確定福利義務現值實際變動情形。

	109年12月31日	108年12月31日
預期 1 年內提撥金額	$ 40,262	$ 39,360
確定福利義務加權平均存續期間	13 年	13 年

十八、權　　益

(一) 普通股股本

	109年12月31日	108年12月31日
額定股數（仟股）	5,000,000	5,000,000
額定股本	$50,000,000	$50,000,000
已發行且已收足股款之股數（仟股）	3,105,196	3,105,196
已發行股本	$31,051,965	$31,051,965

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為 500,000 仟股。

本公司股本變動主要係因股票股利、現金增資及組織重組發行新股。

本公司於 107 年 9 月 4 日董事會決議，為進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業（含資產、負債及營業），並由本公司發行新股予力晶公司作為收購之對價，計發行新股 2,260,818 仟股，並以 108 年 5 月 7 日為收購發行新股基準日，已於 108 年 5 月 13 日辦理變更登記完竣。

本公司經董事會決議現金增資發行新股，並於 108 年 6 月 28 日經董事會決議調整最終股數及募集金額，辦理現金增資發行新股 400,000 仟股，每股面額 10 元，以每股新台幣 10.1 元發行，本次以 108 年 9 月 20 日為增資基準日。

上述現金增資發行新股，依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數之 13.5%由員工認購，其餘之 86.5%計 346,000 仟股，依本公司原股東力晶公司 108 年度股東常會決議將其認購權利讓與力晶公司全體股東。

本公司為配合擴充產能、提升生產製程及增進研發能力所需購置相關設備，於 110 年 3 月 9 日董事會決議，擬現金增資發行新股 300,000 仟股，每股面額 10 元，預計發行後流通在外股數 3,405,196 仟股。

(二) 資本公積

	109年12月31日	108年12月31日
得用以彌補虧損、發放現金或撥充股本(1)		
股票發行溢價	$170,680	$170,680
受贈資產	8	-
僅得用以彌補虧損		
員工認股權執行轉入之金額	11,247	11,247
不得作為任何用途		
發行員工認股權	221,681	-
	$403,616	$181,927

1. 此類資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

(三) 保留盈餘及股利

依本公司 108 年 3 月 12 日修正後章程之盈餘分派政策規定，本公司盈餘分派或虧損彌補得於每半會計年度終了後為之。每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後之。本公司章程規定之員工及董事酬勞分派政策，參閱附註二十之(七)員工酬勞及董事酬勞。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中現金股利於股利總額之 10%～100%，股票股利於股利總額之 0%～90%。

法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。

本公司於 108 年 4 月 12 日董事會（代行股東會職權），決議通過 107 年度盈餘分配案如下：

	盈餘分配表
	107年度
法定盈餘公積	$ 98,593
現金股利	95,234
股票股利	857,109
每股現金股利（元）	0.27
每股股票股利（元）	2.39

本公司於 109 年 5 月 27 日股東常會決議通過 108 年度虧損撥補案，以法定盈餘公積彌補虧損 238,155 仟元。

本公司於 109 年 7 月 28 日董事會決議 109 年上半年度盈餘分配案如下：

	109年1月1日 至6月30日
法定盈餘公積	$ 66,806
現金股利	$ 600,000
每股現金股利（元）	$ 0.19

本公司於 110 年 3 月 9 日董事會擬議 109 年下半年度盈餘分配案如下：

	109年7月1日 至12月31日
法定盈餘公積	$ 169,443
特別盈餘公積	$ 380
現金股利	$ 1,525,867
每股現金股利（元）	$ 0.49

上述現金股利已由董事會決議分配，並預計於 110 年 6 月 9 日召開之股東常會報告。

(四) 其他權益項目

其他權益項目之變動數如下：

109 年度

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額
年初餘額	($ 294)
採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額	(86)
年底餘額	($ 380)

108 年度

	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計
年初餘額	($ 4,316)	$ 356	($ 3,960)
採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額	(294)	39,775	39,481
共同控制下後手由本公司業主權益轉出	4,316	(40,131)	(35,815)
年底餘額	($ 294)	$ -	($ 294)

(五) 庫藏股票

本公司持有之庫藏股票，係 109 年度因受領贈與產生共計 327 股，前述庫藏股票依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派及表決權等權利。

十九、營業收入

	109年度	108年度
客戶合約收入		
商品銷售收入	$45,684,615	$35,897,121

(一) 合約餘額

	109年12月31日	108年12月31日	108年1月1日
應收帳款（附註八）	$ 6,234,704	$ 5,394,884	$ 6,380,859
合約負債			
商品銷售	$ 623,901	$ 808,913	$ 1,138,000
其　　他	77,342	117,446	117,598
	$ 701,243	$ 926,359	$ 1,255,598

來自年初合約負債以及前期已滿足之履約義務於當期認列為收入之金額如下：

	109年度	108年度
來自年初合約負債		
銷貨商品	$552,831	$715,386
其他（帳列其他收益及費損淨額）	92,354	46,922
	$645,185	$762,308

(二) 客戶合約收入之細分

	109年度	108年度
主要地區市場		
台　　灣	$32,938,268	$23,480,915
中　　國	5,814,356	2,223,105
日　　本	1,700,875	1,487,232
其　　他	5,231,116	8,705,869
	$45,684,615	$35,897,121
產品項目		
包裝元件	$ 132,019	$ 382,834
晶　　圓	45,552,596	35,514,287
	$45,684,615	$35,897,121

二十、本年度淨利（損）

(一) 其他收益及費損淨額

	109年度	108年度
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	$ 28,749	$ 950
賠償收入	1,148	141,987
其他收入及支出	181,653	29,078
	$211,550	$172,015

(二) 利息收入

	109年度	108年度
銀行存款	$ 26,679	$ 59,384
附買回債券	1,243	3,093
押金設算息	50	54
	$ 27,972	$ 62,531

(三) 其他利益及損失

	109年度	108年度
外幣兌換淨損失	($305,030)	($ 76,809)
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益	21,504	12,784
	($283,526)	($ 64,025)

(四) 財務成本

	109年度	108年度
借款之利息	$479,135	$437,244
租賃負債之利息	189,059	75,849
其　　他	2	1
	$668,196	$513,094

利息資本化相關資訊如下：

	109年度	108年度
利息資本化金額	$ 37,406	$ 72,899
利息資本化利率	1.98%~2.24%	1.84%~1.98%

(五) 折舊及攤銷

	109年度	108年度
不動產、廠房及設備	$ 5,375,144	$ 4,679,839
使用權資產	476,507	167,884
無形資產	126,621	331,790
合　　計	$ 5,978,272	$ 5,179,513
折舊費用依功能別彙總		
營業成本	$ 5,463,750	$ 4,521,636
營業費用	387,901	325,800
其他收益及費用	-	287
	$ 5,851,651	$ 4,847,723

（接次頁）

（承前頁）

	109年度	108年度
攤銷費用依功能別彙總		
營業成本	$ 109,415	$ 318,401
營業費用	17,206	13,389
	$ 126,621	$ 331,790

(六) 員工福利費用

	109年度	108年度
退職後福利		
確定提撥計畫	$ 328,588	$ 320,001
確定福利計畫（附註十七）	37,425	27,217
	366,013	347,218
股份基礎給付		
權益交割	221,681	11,247
其他員工福利	8,790,817	7,615,105
員工福利費用合計	$ 9,378,511	$ 7,973,570
依功能別彙總		
營業成本	$ 6,390,613	$ 5,298,929
營業費用	2,987,898	2,674,641
	$ 9,378,511	$ 7,973,570

(七) 員工酬勞及董事酬勞

本公司係以當年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本公司稅前淨利，應提撥不低於 5%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

109 年度員工酬勞及董事酬勞於 110 年 3 月 9 日經董事會決議如下：

金　　額

	109年度	
	現　　金	股　　票
員工酬勞	$482,131	$ -
董事酬勞	60,000	-

108 年度係為稅前淨損，故不估列員工酬勞及董監事酬勞。

年度個體財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

107 年度員工酬勞及董監事酬勞之實際配發金額與 107 年度個體財務報告之認列金額並無差異。

二一、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅費用主要組成項目

	109年度	108年度
當期所得稅		
本年度產生者	$ -	$ 6,168
以前年度之調整	4,864	(1,321)
	4,864	4,847
遞延所得稅		
當年度產生者	1,508,155	536,517
與所得稅抵減有關	(525,698)	(515,917)
	982,457	20,600
認列於損益之所得稅費用	$ 987,321	$ 25,447

會計所得與所得稅費用之調節如下：

	109年度	108年度
本年度稅前淨利（損）	$ 4,793,798	($ 2,617,737)
稅前淨利（損）按法定稅率計算之稅額	$ 958,760	($ 528,445)
調節項目之所得稅影響數		
決定課稅所得時不可計入之損益	23,697	15,729
遞延所得稅資產／負債之所得稅影響數	-	533,316
本年度產生者	-	6,168
以前年度之調整	4,864	(1,321)
認列於損益之所得稅費用	$ 987,321	$ 25,447

(二) 本期所得稅資產與負債

	109年12月31日	108年12月31日
本期所得稅資產		
應收退稅款	$ 27,721	$ 11,878
本期所得稅負債		
應付所得稅	$ -	$ -

(三) 遞延所得稅資產與負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

109 年度

	年初餘額	認列於損益	年底餘額
遞延所得稅資產			
虧損扣抵	$ -	$ 525,698	$ 525,698
暫時性差異			
折舊	129,423	43,473	172,896
備抵存貨跌價損失	249,179	(96,264)	152,915
其他	241,984	(67,122)	174,862
	$ 620,586	$ 405,785	$ 1,026,371
遞延所得稅負債			
暫時性差異			
不動產、廠房及設備	$ 607,796	$ 1,328,063	$ 1,935,859
其他	12,790	60,179	72,969
	$ 620,586	$ 1,388,242	$ 2,008,828

108 年度

	年初餘額	共同控制下前手權益轉出數	認列於損益	年底餘額
遞延所得稅資產				
虧損扣抵	$ 588,356	($ 588,356)	$ -	$ -
暫時性差異				
折舊	56,831	-	72,592	129,423
備抵存貨跌價損失	178,992	(176,029)	246,216	249,179
其他	956,531	(912,217)	197,670	241,984
	$ 1,780,710	($ 1,676,602)	$ 516,478	$ 620,586
遞延所得稅負債				
暫時性差異				
不動產、廠房及設備	$ 1,752,678	($ 1,671,567)	$ 526,685	$ 607,796
其他	7,432	(5,035)	10,393	12,790
	$ 1,760,110	($ 1,676,602)	$ 537,078	$ 620,586

(四) 未於個體資產負債表中認列遞延所得稅資產之可減除暫時性差異、未使用虧損扣抵金額及投資抵減稅額

	109年12月31日	108年12月31日
可減除暫時性差異	$ -	$ 405,547
虧損扣抵	$ 2,803,324	$ 2,406,520
投資抵減	$ 85,079	$ -

(五) 未使用之虧損扣抵及投資抵減相關資訊

截至 109 年 12 月 31 日止，虧損扣抵相關資訊如下：

尚未扣抵餘額	最後扣抵年度
$ 2,406,520	118 年度
3,025,291	119 年度
$ 5,431,811	

截至 109 年 12 月 31 日止，投資抵減相關資訊如下：

法令依據	抵減項目	尚未抵減稅額	最後抵減年度
產業創新條例	研究發展支出	$ 55,079	110 年
產業創新條例	智慧機械投資	30,000	110 年
		$ 85,079	

(六) 所得稅核定情形

本公司截至 107 年度以前之營利事業所得稅申報案件業經稅捐稽徵機關核定。

二二、每股盈餘（虧損）

單位：每股元

	109年度	108年度
基本每股盈餘（虧損）	$ 1.23	($ 0.94)
稀釋每股盈餘（虧損）	$ 1.21	($ 0.94)

用以計算每股盈餘（虧損）及普通股加權平均股數如下：

本年度淨利（損）

	109年度	108年度
歸屬於本公司業主之淨利（損）	$ 3,806,477	($ 1,480,370)
歸屬於共同控制下前手權益淨損	-	(1,162,814)
用以計算基本及稀釋每股盈餘（虧損）之淨利（損）	$ 3,806,477	($ 2,643,184)

股　　數　　單位：仟股

	109年度	108年度
用以計算基本每股盈餘（虧損）之普通股加權平均股數	3,105,197	2,821,863
具稀釋作用潛在普通股之影響：		
員工酬勞	45,059	-
用以計算稀釋每股盈餘（虧損）之普通股加權平均股數	3,150,256	2,821,863

若本公司得選擇以股票或現金發放員工酬勞，則計算稀釋每股盈餘時，假設員工酬勞將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。於次年度決議員工酬勞發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

本公司 108 年度因係虧損，若計入員工酬勞之影響將產生反稀釋作用，是以未納入稀釋每股虧損之計算。

本公司將員工認股權憑證之潛在普通股列入計算 109 年度之稀釋每股盈餘時，因具反稀釋作用，故未納入稀釋每股盈餘之股數計算。

二三、股份基礎給付協議

(一) 現金增資保留員工認股

本公司經董事會決議現金增資發行新股，並於 108 年 6 月 28 日經董事會決議調整最終發行股數及募集金額，並依據公司法保留新股總數 13.5%計 54,000 仟股由員工認購。員工認購不足一股之畸零股或放棄認股之股份，則授權董事長洽特定人認購之。

本公司於 108 年 7 月 16 日給與之員工認股權，其公平價值使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之參數如下：

衡量日每股股權公平價值	$ 9.89
行使價格	10.10
預期波動率	30.58%
預期存續期間	0.062 年
預期股利率	-
無風險利率	0.48%
認股權公平價值	0.2083

本公司 108 年度因現金增資保留員工認購權利認列之酬勞成本為 11,247 仟元。

(二) 員工認股權計畫

本公司分別於 109 年 1 月 6 日及 109 年 11 月 10 日經金融監督管理委員會核准發行員工認股權 150,000 仟單位及 300,000 仟單位，每一單位可認購普通股 1 股。認股權之存續期間均為 6 年，憑證持有人於發行屆滿 2 年之日起，可行使被給與之一定比例之認股權。認股權發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時，認股權行使價格依規定公式予以調整。

員工認股權之相關資訊如下：

	109年認股權計畫		108年認股權計畫	
109 年度	單位（仟）	加權平均執行價格（元）	單位（仟）	加權平均執行價格（元）
期初流通在外	-	$ -	-	$ -
本期給與	268,969	15.50	150,000	10.42
本期放棄	(466)	15.50	(4,417)	10.00
期末流通在外	268,503		145,583	
期末可執行	-		-	
本期給與之認股權加權平均公允價值（元）	$ 4.78		$ 3.46	

截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：

	109年12月31日	
認股權計畫	執行價格之範圍（元）	加權平均剩餘合約期限（年）
109 年股權計劃	$ 15.50	5.88
108 年股權計劃	$10.00~15.50	5.13

本公司於 109 年 1 月 20 日董事會通過 108 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	9.28 元
執行價格	10.00 元
預期波動率	42.70%
存續期間	4.87 年
預期股利率	-
無風險利率	0.53%
認股權公平價值	3.25~3.50

本公司於 109 年 11 月 13 日董事會通過 108 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	15.31 元
執行價格	15.50 元
預期波動率	42.58%
存續期間	4.88 年
預期股利率	-
無風險利率	0.22%
認股權公平價值	4.72~4.85

本公司於 109 年 11 月 13 日董事會通過 109 年給與之員工認股權使用 Black-Scholes 評價模式，評價模式所採用之輸入值如下：

衡量日每股股權公允價值	15.31 元
執行價格	15.50 元
預期波動率	42.58%
存續期間	4.88 年
預期股利率	-
無風險利率	0.22%
認股權公平價值	4.72~4.85

109 年度認列之酬勞成本為 221,681 仟元。

二四、現金流量資訊

(一) 非現金交易

	109年度	108年度
不動產、廠房及設備增加數	$ 5,294,294	$ 11,407,264
應付設備款變動數	222,939	408,910
預付設備款變動數	(1,450,212)	295,175
其　　他	(761,975)	54,686
取得不動產、廠房及設備支付現金數	$ 3,305,046	$ 12,166,035

(二) 來自籌資活動之負債變動

109 年度

	109年1月1日	現金流量	非現金之變動 匯率變動	非現金之變動 其他（註）	109年12月31日
長期借款（含一年內到期之長期借款）	$ 26,675,262	($ 3,620,868)	$ -	$ 757,607	$ 23,812,001
存入保證金	490,868	1,127,268	(49,754)	89,436	1,657,818
租賃負債	4,298,869	(264,680)	(216,797)	3,195,682	7,013,074
長期預付款（帳列其他非流動資產－其他）	6,748	79,110	-	(6,699)	79,159
	$ 31,471,747	($ 2,679,170)	($ 266,551)	$ 4,036,026	$ 32,562,052

108 年度

	108年1月1日	現金流量	非現金之變動 匯率變動	非現金之變動 其他（註）	108年12月31日
短期借款	$ 689,435	($ 689,435)	$ -	$ -	$ -
長期借款（含一年內到期之長期借款）	20,015,725	6,601,456	-	58,081	26,675,262
存入保證金	311,120	137,328	(12,903)	55,323	490,868
租賃負債	-	(98,666)	(73,514)	4,471,049	4,298,869
長期預付款（帳列其他非流動資產－其他）	39,458	-	-	(32,710)	6,748
	$ 21,055,738	$ 5,950,683	($ 86,417)	$ 4,551,743	$ 31,471,747

註：其他主要包含來自客戶合約負債轉入、新增租賃負債及租賃負債財務成本。

二五、資本風險管理

本公司進行資本管理係確保公司能夠於繼續經營之前提下，藉由將債務與權益餘額最適化，以使股東報酬極大化。

本公司資本結構係由本公司之淨債務（即借款減除現金及約當現金）、歸屬於母公司業主之權益（即股本、資本公積、保留盈餘及其他權益項目）及非控制權益組成。

二六、金融工具

(一) 公允價值之資訊－非按公允價值衡量之金融工具

本公司管理階層認為非按公允價值衡量之金融資產及金融負債之帳面金額趨近其公允價值。

(二) 公允價值資訊－以重複性基礎按公允價值衡量之金融工具

1. 公允價值層級

109 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 6,798	$ -	$ 6,798

108 年 12 月 31 日

	第 1 等級	第 2 等級	第 3 等級	合計
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
衍生工具	$ -	$ 4,372	$ -	$ 4,372

109及108年度無第1等級與第2等級公允價值衡量間移轉之情形。

2. 第2等級公允價值衡量之評價技術及輸入值

金融工具類別	評價技術及輸入值
衍生工具－遠期外匯合約	現金流量折現法：按期末之可觀察遠期匯率及合約所訂匯率估計未來現金流量，並以可反映各交易對方信用風險之折現率分別折現。

(三) 金融工具之種類

	109年12月31日	108年12月31日
金融資產		
強制透過損益按公允價值衡量	$ 6,798	$ 4,372
按攤銷後成本衡量之金融資產（註1）	14,603,369	11,729,501
金融負債		
按攤銷後成本衡量（註2）	40,628,851	39,335,353

註1：餘額係包含現金及約當現金、應收帳款－非關係人淨額、應收帳款－關係人淨額、其他應收款、其他金融資產及存出保證金等按以攤銷後成本衡量之金融資產。

註2：餘額係包含應付帳款－非關係人、應付設備款、其他應付款、一年內到期之長期借款、租賃負債、長期借款及存入保證金等以攤銷後成本衡量之金融負債。

(四) 財務風險管理目的與政策

本公司之財務風險管理目標，係為管理與營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本公司致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司對於前述財務風險管理已依相關規範建立適當之政策、程序及內部控制，重要財務活動須經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。公司恪遵相關財務操作程序。

1. 市場風險

本公司之營運活動使本公司承擔之主要財務風險為外幣匯率變動風險（參閱下述(1)）及利率變動風險（參閱下述(2)）。本公司從事衍生金融工具（包括遠期外匯）以管理所承擔之外幣匯率。

本公司有關金融工具市場風險之暴險及其對該等暴險之管理與衡量方式並無改變。

(1) 匯率風險

本公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而產生匯率變動風險。本公司匯率風險之管理採部分自然避險，並於政策許可之範圍內，利用遠期外匯合約管理風險。本公司之匯率風險管理，以避險為目的，不以獲利為目的。

本公司於資產負債表日非功能性貨幣計價之貨幣性資產與貨幣性負債帳面金額（包含財務報表中已沖銷之非貨幣性計價之貨幣性項目），參閱附註三十。

敏感度分析

本公司主要受到美金、日幣、歐元及人民幣匯率波動之影響。

下表詳細說明當新台幣（功能性貨幣）對各攸關外幣之匯率增加及減少 1%時，本公司之敏感度分析。敏感度分析僅包括流通在外之外幣貨幣性項目，並將其年末之換算以匯率變動 1%予以調整。敏感度分析之範圍包括現金及約當現金、應收帳款（含關係人）、其他應收款、應付帳款、應付設備款、租賃負債及其他應付款。下表之正數係表示當新台幣相對於各相關貨幣貶值 1%時，將使稅前淨利增加之金額；當新台幣相對於各相關貨幣升值 1%時，其對稅前淨利之影響將為同金額之負數。

	美金之影響		日幣之影響		歐元之影響		人民幣之影響	
	109年度	108年度	109年度	108年度	109年度	108年度	109年度	108年度
損益	$25,755	$19,894	($ 6,213)	($ 4,056)	($ 1,202)	($ 307)	$ 133	$ 130

(2) 利率風險

因本公司內同時以固定及浮動利率借入資金，因而產生利率暴險。本公司定期評估避險活動，以確保採用最符合成本效益之避險策略。

本公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	109年12月31日	108年12月31日
具公允價值利率風險		
一金融資產	$ 4,645,943	$ 4,008,226
一金融負債	(8,613,374)	(5,164,169)
具現金流量利率風險		
一金融資產	3,457,905	1,850,085
一金融負債	(22,211,701)	(25,809,962)

敏感度分析

有關利率風險之敏感性分析，主要針對資產負債表日浮動利率金融負債之現金流量變動為計算基礎。

若利率增加／減少 0.1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司 109 及 108 年度之稅前淨利將分別減少／增加 18,754 仟元及 23,960 仟元，主因為本公司之浮動利率淨負債利率暴險。

2. 信用風險

信用風險係指交易對方拖欠合約義務而造成本公司財務損失之風險。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務及本公司提供財務保證造成財務損失之最大信用風險暴險主要係來自於資產負債表所認列之金融資產帳面金額。

為減輕信用風險，本公司已訂定授信及應收帳款管理辦法，以確保應收帳款之收回，以及逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外，本公司會每季逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。

本公司應收帳款之對象涵蓋眾多客戶，分散於不同產業及地理區域。本公司持續地針對應收帳款客戶之財務狀況每年或不定期進行評估。

個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、信評機構評等、本公司內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。本公司定期或不定期針對應收帳款客戶之財務狀況進行評估，必要時亦會要求客戶提供預收貨款、產能保證金、質押定存或其他擔保品，以降低特定客戶的信用風險。

另因流動資金及衍生金融工具之交易對方係信用良好之銀行，故該信用風險係屬有限。

3. 流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應營運並減輕現金流量波動之影響。

銀行借款對本公司而言係為一項主要流動性風險來源。截至 109 年及 108 年 12 月 31 日止，本公司未動用之融資額度，參閱下列(3)融資額度之說明。

(1) 非衍生金融負債之流動性及利率風險表

非衍生金融負債剩餘合約到期分析係依本公司最早可能被要求還款之日期，按金融負債未折現現金流量（包含本金及估計利息）編製。因此，本公司可被要求立即還款之銀行借款，係列於下表最早之期間內，不考慮銀行立即執行該權利之機率；其他非衍生金融負債到期分析係依照約定之還款日編製。

109 年 12 月 31 日

	1 年以下	1 ～ 5 年	5 年以上	合計
非衍生金融負債				
無附息負債	$ 8,145,958	$ -	$ -	$ 8,145,958
租賃負債	494,973	4,412,787	3,817,566	8,725,326
浮動利率工具	6,223,468	16,034,137	-	22,257,605
固定利率工具	894,062	741,597	-	1,635,659
	$15,758,461	$21,188,521	$ 3,817,566	$40,764,548

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1年以內	1～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上
租賃負債	$ 494,973	$ 4,412,787	$ 1,870,684	$ 638,721	$ 572,376	$ 735,785

108 年 12 月 31 日

	1年以下	1～5年	5年以上	合計
非衍生金融負債				
無附息負債	$ 7,870,354	$ -	$ -	$ 7,870,354
租賃負債	301,111	2,452,181	2,480,436	5,233,728
浮動利率工具	5,539,868	19,414,805	923,800	25,878,473
固定利率工具	15,575	880,833	-	896,408
	$13,726,908	$22,747,819	$ 3,404,236	$39,878,963

租賃負債到期分析之進一步資訊如下：

	1年以內	1～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上
租賃負債	$ 301,111	$ 2,452,181	$ 1,361,842	$ 481,923	$ 442,115	$ 194,556

上述非衍生金融資產及負債之浮動利率工具金額，將因浮動利率與資產負債表日所估計之利率不同而改變。

(2) 衍生金融負債之流動性及利率風險表

針對衍生金融工具之流動性分析，就採淨額交割之衍生工具而言，係以未折現之合約淨現金流入及流出為基礎編製；就採總額交割之衍生工具而言，係以未折現之總現金流入及流出為基礎編製。

109 年 12 月 31 日

	0～3個月	4～6個月	7個月～1年	1至5年	5年以上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流出	($ 633,522)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流入	640,320	-	-	-	-
	$ 6,798	$ -	$ -	$ -	$ -

108 年 12 月 31 日

	0～3個月	4～6個月	7個月～1年	1至5年	5年以上
總額交割					
遠期外匯合約					
一流出	($ 565,342)	$ -	$ -	$ -	$ -
一流入	569,714	-	-	-	-
	$ 4,372	$ -	$ -	$ -	$ -

(3) 融資額度

	109年12月31日	108年12月31日
無擔保金融業及非金融業透支額度		
－已動用金額	$ 175,000	$ 525,000
－未動用金額	2,000,000	2,300,000
	$ 2,175,000	$ 2,825,000
有擔保金融業及非金融業透支額度		
－已動用金額	$ 23,637,001	$ 26,150,262
－未動用金額	29,847,000	2,466,000
	$ 53,484,001	$ 28,616,262

二七、關係人交易

本公司與關係人間之交易如下：

(一) 關係人名稱及其關係

關係人名稱	與本公司之關係
力晶公司	本公司之母公司（109 年 9 月 24 日後為對本公司具重大影響力之公司）
PowerMemory Inc.	子公司
Maxram Inc.	子公司
黃崇仁	主要管理階層
吳明長	主要管理階層
林盈禎	主要管理階層
陳瑞隆	主要管理階層
謝再居	主要管理階層
童貴聰	主要管理階層
朱憲國	主要管理階層
謝明霖	主要管理階層
劉志能	主要管理階層
徐震球	主要管理階層（109 年 4 月 10 日退休後為非關係人）
台灣光罩股份有限公司	實質關係人（109 年 9 月 24 日後為非關係人）
智立投資股份有限公司	實質關係人（109 年 9 月 24 日後為非關係人）
智豐科技股份有限公司	實質關係人
黃毓秀	實質關係人
Zentel Japan Corporation	實質關係人

（接次頁）

（承前頁）

關係人名稱	與本公司之關係
財團法人力晶文化基金會	實質關係人
力晶積成電子製造股份有限公司職工福利委員會	實質關係人
世成科技股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為實質關係人）
智成電子股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為實質關係人）
合肥晶合集成電路有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為非關係人）
智仁科技開發股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為實質關係人）
世仁投資股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為對本公司具重大影響力之公司之合併個體）
力信投資股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為對本公司具重大影響力之公司之合併個體）
智典國際股份有限公司	關聯企業（109 年 9 月 24 日後為對本公司具重大影響力之公司之合併個體）

(二) 營業收入

	109年度	108年度
實質關係人	$ 2,378,934	$ 1,656,474
關聯企業	-	214
	$ 2,378,934	$ 1,656,688

(三) 進　　貨

	109年度	108年度
母公司	$ -	$ 1,353

(四) 取得之不動產、廠房及設備

	取得價款	
	109年度	108年度
實質關係人	$ 1,000,000	$ -

(五) 銷貨成本—權利金

	109年度	108年度
關聯企業	$ 14,846	$ 18,900
實質關係人	4,807	-
	$ 19,653	$ 18,900

(六) 製造費用

	109年度	108年度
實質關係人	$ 289	$ 340

(七) 管理費用

	109年度	108年度
實質關係人	$ 20,095	$ 1,470
關聯企業	469	581
	$ 20,564	$ 2,051

(八) 研發費用

	109年度	108年度
子 公 司	$164,215	$ 98,945
實質關係人	21,593	206
關聯企業	17,885	101,712
	$203,693	$200,863

(九) 其他收益及費損淨額

	109年度	108年度
母 公 司	$ 1	$ -
主要管理階層	35	1
實質關係人	8,858	7,548
關聯企業	-	1,637
	$ 8,894	$ 9,186

(十) 應收帳款

	109年12月31日	108年12月31日
實質關係人	$253,494	$ 49,914

(十一) 向關係人借款（帳列長期借款）：

	109年12月31日	108年12月31日
實質關係人	$735,000	$ -

財務成本

	109年度	108年度
實質關係人	$ 9,533	$ -
關聯企業	-	1,641
	$ 9,533	$ 1,641

本公司向關係人借款之借款利率於 109 年 12 月 31 日為 1.80%。上列借款為擔保借款。

(十二) 合約負債

	109年12月31日	108年12月31日
實質關係人	$ 20,391	$ -

(十三) 其他應付款

	109年12月31日	108年12月31日
主要管理階層	$ -	$ 2,201
實質關係人	12,502	84
關聯企業	-	114,988
	$ 12,502	$117,273

(十四) 存出保證金

	109年12月31日	108年12月31日
主要管理階層	$ 1	$ 1
實質關係人	1	1
	$ 2	$ 2

本公司與關係人間晶圓代工之銷貨價格，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司支付關係人間之權利金、本公司與關係人之進貨價格，係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人之取得不動產、廠房及設備係依雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人之製造費用、管理費用及研發費用係依雙方議定之合作協議，並無其他適當交易對象可資比較。

本公司與關係人間之其他收益及費損，係依據雙方議定之條件為之，並無其他適當交易對象可資比較。

流通在外之應收關係人款項未收取保證金或任何擔保品。

本公司合約負債之銷貨條件，係與客戶交易時參考市場行情，議定價格及數量。

上述之其他應付關係人款項主要係技術開發、權利金費用及利息費用產生。

除上述交易外，本公司與其他關係人間之交易，係按一般交易條件及價格辦理。

(十五) 承租協議

關係人類別／名稱	109年度	108年度
取得使用權資產		
實質關係人	$ -	$ 4,946

帳列項目	關係人類別／名稱	109年12月31日	108年12月31日
租賃負債－流動	主要管理階層	$ 81	$ 80
	實質關係人	12,251	2,619
	關聯企業	-	6,911
		$ 12,332	$ 9,610
租賃負債－非流動	主要管理階層	$ 165	$ 245
	實質關係人	24,831	1,916
	關聯企業	-	21,100
		$ 24,996	$ 23,261

關係人類別／名稱	關係人類別／名稱	109年度	108年度
財務成本	主要管理階層	$ 5	$ 9
	實質關係人	226	51
	關聯企業	558	898
		$ 789	$ 958

本公司向關係人承租辦公室、停車位及公務車，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金定期支付。

(十六) 主要管理階層薪酬

109 及 108 年度對董事及其他主要管理階層之薪酬總額如下：

	109年度	108年度
短期員工福利	$248,901	$160,663
退職後福利	38,227	22,723
	$287,128	$183,386

董事及其他主要管理階層之薪酬係依照個人績效及市場趨勢決定。

二八、質抵押之資產

本公司下列資產已提供作為長期借款、天然氣使用、承租科管局土地及保稅品出區之擔保品：

	109年12月31日	108年12月31日
不動產、廠房及設備	$ 34,146,212	$ 27,454,063
受限制存款（帳列其他金融資產）	1,892,931	1,896,531
	$ 36,039,143	$ 29,350,594

二九、重大或有負債及未認列之合約承諾

除其他附註所述者外，本公司於資產負債表日有下列重大承諾事項及或有事項：

(一) 本公司分別於 92 年 8 月、94 年 3 月、97 年 6 月、99 年 3 月、10 月、100 年 7 月及 102 年 7 月與 Micron Memory Japan, Inc.（原 Elpida Memory Inc.）簽署若干動態隨機存取記憶體技術移轉與授權合約，本公司承諾自技術移轉完成後 5 年內支付一定金額之技術授權費及依約定產品之售價給付一定比例之權利金。惟雙方另於 100 年 5 月及 102 年 7 月簽署合作協議，修訂權利金支付比例。

(二) 本公司分別於 92 年 8 月及 94 年 3 月與某公司簽署若干動態隨機存取記憶體技術之專利授權合約，本公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(三) 本公司於 92 年 8 月與某公司等簽署若干動態隨機存取記憶體之專利技術授權合約，本公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(四) 本公司於108年7月與愛爾蘭商遠東金士頓公司簽訂代工合約至110年10月31日止，本公司承諾以約定價格為其製造記憶體產品。

三十、具重大影響之外幣資產及負債資訊

以下資訊係按本公司功能性貨幣以外之外幣彙總表達，所揭露之匯率係指該等外幣換算至功能性貨幣之匯率。具重大影響之外幣資產及負債如下：

	109年12月31日			108年12月31日		
	外幣	匯率	帳面價值	外幣	匯率	帳面價值
外幣資產						
貨幣性項目						
美金	$ 361,770	28.372	$ 10,264,138	$ 225,863	30.046	$ 6,786,284
歐元	227	34.89	7,926	58	33.66	1,944
日幣	219,508	0.2751	60,387	941,145	0.2766	260,321
人民幣	3,059	4.34	13,275	3,006	4.31	12,955
外幣負債						
貨幣性項目						
美金	270,993	28.372	7,688,620	159,650	30.046	4,796,840
歐元	3,671	34.89	128,097	969	33.66	32,606
日幣	2,478,059	0.2751	681,714	2,407,362	0.2766	665,876

本公司主要承擔美金及新台幣之外幣匯率風險。具重大影響之外幣兌換損益（已實現及未實現）如下：

	109年度		108年度	
功能性貨幣	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益	功能性貨幣兌表達貨幣	淨兌換（損）益
新台幣	1（新台幣：新台幣）	($ 305,030)	1（新台幣：新台幣）	($ 76,809)

三一、附註揭露事項

(一) 重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊：

1. 資金貸與他人。(無)
2. 為他人背書保證。(無)
3. 期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)。(無)
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新臺幣 3 億元或實收資本額 20%以上。(無)
5. 取得不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上。(無)
6. 處分不動產之金額達新臺幣3億元或實收資本額20%以上。(無)
7. 與關係人進、銷貨之金額達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。(附表一)

8. 應收關係人款項達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上。(附表二)

9. 從事衍生工具交易。(本公司從事衍生性商品相關資訊請參閱附註七及二六)

10. 被投資公司資訊、所在地區…等相關資訊。(附表三)

(三) 大陸投資資訊：

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。(無)

2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，及其價格、付款條件、未實現損益。(無)

(四) 主要股東資訊：股權比例達 5%以上之股東名稱、持股數額及比例。(附表四)

力晶積成電子製造股份有限公司

與關係人進、銷貨交易金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20%以上

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：新台幣仟元

進（銷）貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收（付）票據、帳款		備註
			進／銷貨	金額	佔總進／銷貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收（付）票據、帳款之比率	
本公司	智豐科技股份有限公司	實質關係人	銷貨	$ 1,472,901	3%	註 1	$ -	—	$ 151,421	2%	
	Zentel Japan Corporation	實質關係人	銷貨	903,134	2%	註 2	-	—	102,073	2%	

註 1： 主要係月結 60 天付款。

註 2： 主要係月結 30 天及貨到 30 天付款。

力晶積成電子製造股份有限公司

應收關係人款項達新臺幣 1 億元或實收資本額 20%以上

民國 109 年 12 月 31 日

附表二

單位：除另予註明者外，為新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵損失金額
					金額	處理方式		
本公司	智豐科技股份有限公司	實質關係人	$ 151,421	19.45 次	$ -	—	$ 151,421	$ -
本公司	Zentel Japan Corporation	實質關係人	102,073	11.88 次	-	—	102,073	-

力晶積成電子製造股份有限公司

被投資公司資訊、所在地區...等相關資訊

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表三

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數（仟股）	比率（%）	帳面金額			
本公司	Global Powertec Co., Ltd.	英屬維京群島	從事各式投資業務	$ 1	$ 1	-	100	($ 78,244)	($ 20,719)	($ 20,719)	

力晶積成電子製造股份有限公司

主要股東資訊

民國 109 年 12 月 31 日

附表四

主要股東名稱	股份	
	持有股數（股）	持股比例
力晶科技股份有限公司	825,691,640	26.59%

註 1： 本表主要股東資訊係由集保公司以當季季底最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付（含庫藏股）之普通股及特別股合計達 5%以上資料。本公司個體財務報告所記載股本與實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

註 2： 上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過 10%之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

【附件六】

內部控制聲明書

力晶積成電子製造股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：110年7月13日

本公司民國109年4月1日至110年3月31日之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國110年3月31日之內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、為申請股票上市之需要，本公司依據「處理準則」第二十五條及「臺灣證券交易所股份有限公司審查有價證券上市作業程序」第六條之規定，委託會計師專案審查上開期間與外部財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情況下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前項所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情況下逕行取得、使用或處分之重大缺失。

七、本聲明書將成為本公司公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

八、本聲明書業經本公司民國110年7月13日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

力晶積成電子製造股份有限公司

董事長：

總經理：

【附件七】

內部控制制度審查報告

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
30078 新竹市東區科學工業園區展業一路2號6樓

Deloitte & Touche
6F, Allied Association Industries
No. 2, Zhanye 1st Rd., Hsinchu Science Park
East Dist., Hsinchu 30078, Taiwan

Tel :+886 (3) 578-0899
Fax:+886 (3) 405-5999
www.deloitte.com.tw

內部控制制度審查報告

後附力晶積成電子製造股份有限公司民國 110 年 7 月 13 日謂經評估認為其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 109 年 4 月 1 日至 110 年 3 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師審查竣事。維持有效之內部控制制度及評估其有效性係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據審查結果對公司內部控制制度之有效性及上開公司之內部控制制度聲明書表示意見。

本會計師係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及一般公認審計準則規劃並執行審查工作，以合理確信公司上述內部控制制度是否在所有重大方面維持有效性。此項審查工作包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之意見提供合理之依據。

任何內部控制制度均有其先天上之限制，故力晶積成電子製造股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制有效性判斷項目判斷，力晶積成電子製造股份有限公司與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 109 年 4 月 1 日至 110 年 3 月 31 日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性；力晶積成電子製造股份有限公司於民國 110 年 7 月 13 日所出具謂經評估認為其上述與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　黃　裕　峰

會計師　鍾　鳴　遠

中　華　民　國　110　年　7　月　20　日

【附件八】

證券承銷商評估總結意見

承銷商總結意見

力晶積成電子製造股份有限公司(以下簡稱力積電或該公司)本次為辦理初次上市現金增資發行普通股130,000千股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總額為新台幣1,300,000千元整，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，力積電本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

承銷部門主管：林佩宸

中　華　民　國　一　一　〇　年　10　月　19　日

【附件九】

律師法律意見書

律師法律意見書

力晶積成電子製造股份有限公司本次為申請股票上市，向臺灣證券交易所股份有限公司提出股票上市交易申請。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「臺灣證券交易所股份有限公司審查有價證券上市作業程序」、「臺灣證券交易所股份有限公司初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」等規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，力晶積成電子製造股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市，並未發現有違反法令致影響股票上市之情事。

此致

力晶積成電子製造股份有限公司

傑宇法律事務所

陳維鈞律師

中　華　民　國　一　一　〇　年　7　月　29　日

律師法律意見書

力晶積成電子製造股份有限公司本次為募集與發行普通股130,000,000股、每股面額新台幣10元、總金額1,300,000,000元，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，力晶積成電子製造股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

力晶積成電子製造股份有限公司

傑宇法律事務所

陳維鈞律師

中華民國110年10月19日

【附件十】

不得退還或收取承銷相關費用之聲明書

聲明書

本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

發行人：力晶積成電子製造股份有限公司

負責人：黃崇仁

中華民國 110 年 10 月 19 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董　事：黃崇仁

中華民國　110　年　10　月　19　日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董　事：謝再居 謝再居

中 華 民 國　110 年　10 月　8 日

聲明書

本公司為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之法人董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董　事：仁典投資股份有限公司

負責人：洪志賢

中華民國　110　年　10　月　19　日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之法人董事代表人，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事代表人：邵章榮

邵章榮

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本公司為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之法人董事，於該公司公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

董　事：力晶科技股份有限公司

負責人：黃崇仁

中華民國　110　年　10　月　19　日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司公司」）之法人董事代表人，於該公司公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

法人董事代表人：徐清祥　徐清祥

中華民國　110　年　10　月　19　日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之獨立董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：張嘉臨

張嘉臨

中華民國110年 10月8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之獨立董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：林本堅 林本堅

中華民國 110 年 10 月 12 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之獨立董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：吳重雨

中華民國 110 年 10 月 19 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之獨立董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：林憲銘　林憲銘

中華民國　110　年　10　月　8　日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「該公司」）之獨立董事，於該公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司、該公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與該公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

獨立董事：葉疏

葉疏

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：黃崇仁

中華民國 110 年 10 月 19 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：陳俊良 陳俊良

中華民國 110 年 10 月 13 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：王炳堯　王炳堯

中華民國　110　年　10　月　8　日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：顧峻

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：謝再居

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：簡文勝 簡文勝

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：林保全

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：譚仲民 譚仲民

中華民國 110 年 10 月 13 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：謝明霖

謝明霖

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：邱垂源 邱垂源

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：張守仁

張守仁

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：陳章鑑

中華民國 110 年 10 月 19 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：邵章榮

邵章榮

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：許梅珊

中華民國 110 年 10 月 19 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：吳德源 吳德源

中華民國 110 年 10 月 08 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：劉志能 劉志能

中華民國 110 年 10 月 19 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：姜建德 姜建德

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：林盈禎

林盈禎

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：蔡明勳

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：劉堅松　劉堅松

中華民國　110　年　10　月　12　日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：龐忠義 龐忠義

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：施奕強

施奕強

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：朱憲國

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：吳元雄

中華民國 110 年 10 月 13 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：陳冠州

陳冠州

中華民國 110 年 10 月 13 日

聲明書

本人為力晶積成電子製造股份有限公司（下稱「本公司」）之經理人，於本公司申報募集與發行普通股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行普通股乙案有關之經理人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

經理人：吳明長

中華民國 110 年 10 月 8 日

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

日　期：110、10、19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

負責人：王濬智

日　期：110、10、19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司

董　　事　　長：陳俊宏

日　期：　110.10.19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司

董　　事　　長：陳俊宏

日　期：　110.10.19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：臺灣土地銀行股份有限公司

代表人：董事長 謝娟娟

代理人：證券部經理 謝瑞員

日　期：110、10、19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：黃進明

日　期：110.10.19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳佩君

日　期：110.10.19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：彰化商業銀行股份有限公司

負責人：凌忠嫄

日　期：110.10.19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：台新綜合證券股份有限公司

負責人：郭

日　期：110.10.19

聲明書

本公司受力晶積成電子製造股份有限公司（下稱力積電公司）委託，擔任該公司募集與發行普通股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、力積電公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

協辦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

負責人：謝　政　雄

日　期：110.10.19

【附件十一】

無非常規交易聲明書

聲　明　書

本公司聲明與集團企業公司(詳附件)間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後若有財務、業務往來時，將依本公司所訂之各項管理制度規章正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：力晶積成電子製造股份有限公司

代　表　人：黃崇仁

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

附件

集團企業：

1. 力晶科技股份有限公司
2. Global Powertec Co., Ltd
3. PowerMemory Inc.
4. Maxram Inc.
5. 世仁投資股份有限公司
6. 力信投資股份有限公司
7. 富碩投資股份有限公司
8. 智典國際股份有限公司

聲　明　書

本公司聲明與力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後有交易往來時，將依本公司內部控制制度及相關規定正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：Global Powertec Co., Ltd

代 表 人：

For and on behalf of
Global Powertec CO., LTD.

Authorised Signature(s)

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲　明　書

本公司聲明與力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後有交易往來時，將依本公司內部控制制度及相關規定正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：力晶科技股份有限公司

代　表　人：黃崇仁

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲　明　書

本公司聲明與力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後有交易往來時，將依本公司內部控制制度及相關規定正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：PowerMemory Inc.

代　表　人：Power Memory 株式會社

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲　明　書

本公司聲明與力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後有交易往來時，將依本公司內部控制制度及相關規定正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：Maxram Inc.

代　表　人：

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲　明　書

本公司聲明與力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後有交易往來時，將依本公司內部控制制度及相關規定正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：世仁投資股份有限公司

代　表　人：張亦中

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲　明　書

本公司聲明與力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後有交易往來時，將依本公司內部控制制度及相關規定正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：力信投資股份有限公司
代　表　人：羅英華

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲　明　書

本公司聲明與力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後有交易往來時，將依本公司內部控制制度及相關規定正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：智典國際股份有限公司
代　表　人：羅英華

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲　明　書

本公司聲明與力晶積成電子製造股份有限公司及其子公司間有財務、業務往來者，並無非常規交易；無財務、業務往來者，承諾日後有交易往來時，將依本公司內部控制制度及相關規定正常運作，且無非常規交易之情事。

特此聲明

公 司 名 稱：富碩投資股份有限公司

代 表 人 ： 陳吉元

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

【附件十二】

不受理特定對象投標聲明書

聲明書

茲聲明本公司本次辦理初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

發行公司：力晶積成電子製造股份有限公司

負責人：黃崇仁

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
八、承銷團各證券商。
九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：黃進明

中華民國　110　年　10　月　19　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：臺灣土地銀行股份有限公司

代表人：董事長 謝娟娟

代理人：證券部經理 謝瑞員

中 華 民 國　110　年　10　月　19　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳佩君

陳佩君
公務專用章

中　華　民　國　　110　　年　　10　　月　　19　　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：台新綜合證券股份有限公司

負責人：[illegible]

中　華　民　國　110.　年　10　月　19　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

負責人：謝　政　雄

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。
四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。
八、承銷團各證券商。
九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。
十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：第一金證券股份有限公司

負責人：陳致全

中華民國　110　年　10　月　19　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：彰化商業銀行股份有限公司

負責人：凌忠嫄

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲明書

茲聲明本公司本次辦理力晶積成電子製造股份有限公司初次上市前現金增資發行新股將不受理下列對象之投標單：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

特此聲明

此　　致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

負責人：王濬智

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

聲 明 書

茲聲明本公司協辦力晶積成電子製造股份有限公司初次上市現金增資發行新股案件，如發現競價拍賣投標之對象有下列各款之人應募時，應拒絕之：

一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。

二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。

三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶關係者。

四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。

五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。

六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。

七、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶。

八、承銷團各證券商。

九、擔任興櫃股票公司辦理增資發行新股為初次上市（櫃）公開銷售時之推薦證券商。

十、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

聲明人：元富證券股份有限公司

董事長：陳俊宏

中　華　民　國　110　年　10　月　19　日

【附件十三】

誠信聲明書

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董　事：黃崇仁

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董　事：謝再居

中華民國　110 年　10 月　8 日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董　事：仁典投資股份有限公司

負責人：洪志賢

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

法人董事代表人：邵章榮

邵章榮

中華民國 110 年 10 月 8 日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、 切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

董　事：力晶科技股份有限公司

負責人：黃崇仁

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

法人董事代表人：徐清祥 徐清祥

中華民國 110 年 10 月 19 日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：葉疏 葉 疏

中華民國 110 年 10 月 8 日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：林憲銘 林憲銘

中華民國 110 年 10 月 8 日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：吳重雨 吳重雨

中華民國 110 年 10 月 19 日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：林本堅 林本堅

中華民國 110 年 10 月 12 日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上市案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第171條、第174條及其他相關法律之責任。

1、 切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

2、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

獨立董事：張嘉臨

張嘉臨

中華民國110年10月8日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：黃崇仁

中華民國 110 年 10 月 19 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：譚仲民 譚仲民

中華民國 110 年 10 月 13 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：王炳堯　王炳堯 2021.10.8

中華民國　110　年　10　月　8　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：顧峻

中華民國　110 年　10 月　8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：謝再居

中華民國　110 年　10 月　8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：簡文勝　簡文勝

中華民國　110　年　10　月　8　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：林保全

中華民國　110　年　10　月　8　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：謝明霖

謝明霖

中華民國 110 年 10 月 8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：邱垂源 邱垂源

中華民國 110 年 10 月 8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：張守仁

張守仁

中華民國　110　年　10　月　8　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：陳章鑑

中華民國　110　年　10　月　19　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：邵章榮

邵章榮

中華民國 110 年 10 月 8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：許梅珊

中華民國　110　年　10　月　19　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：吳德源　吳德源

中華民國　110　年　10　月　08　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：姜建德 姜建德

中華民國 110 年 10 月 8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：林盈禎　林盈禎

中華民國　110　年　10　月　8　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：蔡明勳 蔡明勳

中華民國 110 年 10 月 8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：劉堅松　劉堅松

中華民國　110　年　10　月　12　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、 切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、 知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：龐忠義

中華民國　110　年　10　月　8　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：施奕強

施奕強

中華民國　110　年　10　月　8　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：朱憲國

中華民國 110 年 10 月 8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：吳元雄

中華民國　110　年　10　月　13　日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：陳冠州

陳冠州

中華民國　110 年　10 月　13 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：吳明長

中華民國 110 年 10 月 8 日

本人為力晶積成電子製造股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

經理人：陳俊良　陳俊良

中華民國 110 年 10 月 13 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

負責人：王　濬　智

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

九、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

十、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：台新綜合證券股份有限公司

負責人：郭

中華民國 110. 年 10 月 19 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

五、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

六、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：彰化商業銀行股份有限公司

負責人：凌忠嫄

中華民國　110　年　10　月　19　日

2

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

三、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

四、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：黃　進　明

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：臺灣土地銀行股份有限公司

代表人：董事長 謝娟娟

代理人：證券部經理 謝瑞員

中華民國 110 年 10 月 19 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳　佩　君

陳佩君
公務專用章

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司

董　事　長：陳俊宏

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：第一金證券股份有限公司

負責人：陳　致　全

中華民國　110　年　10　月　19　日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依　貴公司相關規定處理，並自負證券交易法第56條、第66條、第171條、第174條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第36條及第43條之1有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

協辦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

負責人：謝　政　雄

中華民國　110　年　10　月　19　日

本會計師承辦力晶積成電子製造股份有限公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師：黃裕峰

會計師：鍾鳴遠

中華民國 110 年 7 月 30 日

本律師承辦力晶積成電子製造股份公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

律師事務所：傑宇法律事務所

律師：陳維鈞

中華民國 110 年 7 月 30 日

本律師承辦力晶積成電子製造股份公司申請有價證券上市案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43 條之 1 有關承銷禁止參與對象之規定。

特此聲明

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

律師事務所：翰辰法律事務所

律師：邱雅文律師

中華民國 110 年 7 月 30 日

【附件十四】

與本次發行有關之決議文(含盈餘分配表)

力晶積成電子製造股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄(節錄本)

一、時間：一一〇年七月二日（星期五）上午九時整

二、地點：新竹市明湖路 773 號煙波大飯店

三、出席：本公司已發行股份總數：3,105,196,242 股（已扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份，截至原訂股東常會日期一一〇年六月九日，本公司無表決權股數 327 股）

親自及委託出席股數：2,073,219,390 股

親自及委託出席股數佔全部已發行股數：66.76%

四、主席：董事長：黃崇仁　　紀錄：許梅珊

列席：鍾鳴遠會計師、陳錦隆律師

親自及委託出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

五、主席致詞：＜略＞。

六、報告事項：＜略＞。

七、承認事項：＜略＞。

八、選舉事項：＜略＞。

九、討論事項：

第一案　　董事會提

案由：擬向臺灣證券交易所申請股票上市案，提請　核議。

說明：1.為配合長期經營發展目標、延攬優秀專業人才及邁向資本大眾化，以達永續經營之目的，本公司擬於適當時機向臺灣證券交易所提出股票上市申請。

2.有關股票上市之申請時程與相關事宜，擬授權董事長配合相關法令規定全權處理之。

決議：本案表決結果已達法令規定標準照案通過。

投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：2,703,219,390 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：1,959,611,237 權	94.52%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：113,608,153 權	5.47%

第二案　　董事會提

案由：辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案，提請　核議。

說明：1.本公司為配合申請股票上市規定，擬俟主管機關核准上市申請案後，於適當時機辦理現金增資發行新股，至少應提出擬上市股份總額百分之十之股份或得以不低於二千萬股之股數，作為初次上市前提出公開承銷之新股來源。

2.本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留發行新股之 10%~15%由員工認購，員工放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人認購之。

3.除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%擬依證券交易法第 28 條之 1 及相關申請股票上市之法令規定，由原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用，不受公司法第 267 條關於原股東按照原有股份比例儘先分認之規定限制。

4.本次現金增資計畫之重要內容(包括發行價格、實際發行股數、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及相關事項等)，暨其他一切有關本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更、客觀環境改變或其他事實需要予以修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

5.本次增資發行新股之權利與義務與已發行股份相同。

6.依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上市前採行承銷方式，擬提請股東會授權董事會視市場狀況決定之。

7.本案俟股東會通過並呈主管機關核准後，另行召開董事會訂定認股繳款暨增資基準日及辦理發行新股等相關事宜。

決議：本案表決結果已達法令規定標準照案通過。

投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：2,073,219,390 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：1,959,502,460 權	94.51%
反對權數：108,777 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：113,608,153 權	5.47%

第三案～ 第八案：＜略＞。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣佈散會：

散會時間：同日上午十時三十四分。

力晶積成電子製造股份有限公司
一一〇年度第八屆第十次董事會 議事錄(節錄本)

壹、時間：一一〇年十月十九日(星期二)下午三時

貳、地點：台北市南京東路三段六十八號十五樓

參、主席：董事長黃崇仁先生　　紀錄：許梅珊

出(列)席情形：詳附錄—第 59 頁

肆、主席致詞：＜略＞。

伍、報告事項＜略＞。

陸、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

案(一)：＜略＞。

案(二)：本公司擬辦理初次上市前對外公開承銷現金增資發行新股案，敬請 討論。

說 明：1.本公司股票初次上市申請案，業經臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 09 月 16 日審議會及 110 年 09 月 28 日董事會決議通過。

2.本公司業於 110 年 07 月 02 日股東常會決議通過辦理初次申請股票上市前之現金增資案，作為初次上市前提出公開承銷之新股來源，並授權董事會辦理發行新股等相關事宜。

3.本次擬定辦理現金增資發行新股 130,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，預計增加股本新台幣 1,300,000,000 元，預計每股發行價格暫定為新台幣 50 元溢價發行，預計募集總金額計新台幣 6,500,000,000 元。惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格與實際發行價格，擬提請董事會授權董事長參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之，暫訂每股發行價格之合理性說明，請詳＜附件 11＞-第 39 頁~第 54 頁。

4.本次增資發行新股除依公司法第 267 條規定，保留發行新股總額 15%即 19,500,000 股予員工認購，員工認股辦法擬授權董事長核定之；其餘 85%即 110,500,000 股依證券交易法第 28 條之 1 規定及 110 年 07 月 02 日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先分認規定之限制。本次員工放棄認股之股份或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

5.本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行新股之權利義務與原已發行股份相同；有關本次現金增資之計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益，請詳＜附件 12＞-第 55 頁。

6.本次現金增資計畫之重要內容(包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等)，暨其他一切有關本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。

7.本次現金增資發行普通股案，俟陳報主管機關申報生效後，授權董事長另訂繳款期間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

8.本公司上市前之相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌，授權董事長全權處理之。

9.本案業經 110 年 10 月 19 日第一屆第八次審計委員會審議通過在案。

10.敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

案(三) ～案(四)：＜略＞。

柒、臨時動議：無。

捌、其他應記載事項：無。

玖、散　　會：同日下午三時三十分。

力晶積成電子製造股份有限公司

民國109年度

單位：新台幣元

項目	金額	
期初累積虧損		(1,357,218,053)
減：確定福利計劃再衡量數	(86,763,942)	
加：109 年稅後純益	3,806,477,144	
減：特別盈餘公積	(380,093)	
減：法定盈餘公積		
109 年上半年提列數	(66,806,409)	
109 年下半年提列數	(169,443,106)	
本期可供分配盈餘		2,125,865,541
分配項目:		
109 年上半年度分配現金股利(每股新台幣 0.19322448 元)		(600,000,000)
109 年下半年度分配現金股利(每股新台幣 0.49139101 元)		(1,525,865,541)
期末未分配盈餘		0

董事長：黃崇仁　　經理人：謝再居　　主辦會計：邱垂源

【附件十五】

公司章程及新舊條文對照表

力晶積成電子製造股份有限公司章程

第一節　總　　則

第　一　條：本公司依中華民國公司法之規定組織之，定名為「力晶積成電子製造股份有限公司」，英文名稱定為「Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation」。

第　二　條：本公司經營業務範圍：

CC01080 電子零組件製造業。

F401010 國際貿易業。

I599990 其他設計業。

F601010 智慧財產權業。

【1. 各式積體電路之研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工、銷售。

2. 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

3. 各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝。(限區外經營)

4. 半導體設備零組件維修、開發、製造與銷售。

5. 研究、開發、設計及銷售下列產品：

(1) 特殊應用積體電路技術整合服務

(2) 矽智財設計與服務】

第　三　條：本公司得為有關業務之對外保證。

第　四　條：本公司對外投資依本公司董事會決議為之，其投資總額不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十之限制。

第　五　條：本公司設總公司於新竹科學工業園區內，且應其業務活動之需要，經董事會之決議及主管機關同意後於中華民國領域內及領域外，設立代表人辦事處與分公司。

第　六　條：本公司之公告，依公司法第二十八條規定辦理。

第二節　股　　份

第　七　條：本公司資本總額定為新台幣伍佰億元，共分為伍拾億股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。前項資本總額中，保留新台幣伍拾億元，分為伍億股，每股面額新台幣壹拾元，係本公司之員工認股權憑證數額，授權董事會分次發行。授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。

本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合董事會所訂定條件之控制或從屬公司員工。

第　八　條：本公司發行之股份，得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構辦理登錄。

第　九　條：本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第　十　條：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內或公司決定分派股息、紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

第三節　股 東 會

第　十一　條：本公司股東會分下列二種：

1.股東常會，每年至少召集一次。

2.股東臨時會，於必要時召集之。

股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。

第　十二　條：股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前，以書面通知各股東、對於持有記名股票未滿一千股股東，得以公告方式為之。書面通知及公告應載明召集股東會之事由。

第　十三　條：本公司召開股東常會時持有已發行股份總數百分之一之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列作議案，其相關作業依公司法及相關規定辦理之。

第　十四　條：除中華民國公司法另有規定外，股東會應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，方得開議，而股東之出席得由股東親自出席或出具委託書由他人代為出席；其決議應有出席股東表決權過半數之同意行之。

第　十五　條：本公司股東每股有一表決權。但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第　十六　條：股東不能出席股東會時，得依中華民國公司法第一百七十七條規定，委託代理人代表出席，並行使其權利。代理人不以本公司股東為限。

股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條及證券交易法第二十五條之一規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第　十七　條：本公司於召開股東會時，本公司應提供股東以書面或電子作為行使表決權方式，股東得以書面或電子方式行使表決權，其以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，相關事宜悉依法令規定辦理。

第　十八　條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第　十九　條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。該議事錄應與出席股東之簽名簿及代表出席委託書一併保存於本公司。

第十九條之一：本公司於股票公開發行後，非經股東會決議，不得辦理撤銷公開發行。

前項內容於本公司櫃檯交易買賣期間或上市期間不得變更。

第四節　董事及審計委員會

第　二十　條：本公司設董事五至十三人，由股東會就候選人名單中選任之。全體董事所持記名股票之股份總額，依主管機關之規定辦理。

本公司得經董事會決議為董事及重要職員於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其投保責任保險，相關保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第二十條之一：本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第二十條之二：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供資源等事項，以審計委員會組織規程另訂之。

第 二十一 條：董事任期為三年，連選得連任。

第 二十二 條：除中華民國公司法另有規定者外，董事會應有半數以上董事出席，方得開議，其決議應以出席董事過半數之同意行之。

第 二十三 條：董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事長對外代表本公司。並得設副董事長一人以協助董事長。

第 二十四 條：除每屆第一次董事會，由所得選票最多之董事於改選後十五天內召集外，董事會應由董事長召集之。董事會之召集應載明會議日期地點及議程，至少於開會七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知。

第 二十五 條：董事長為董事會主席。另外，董事長有權依董事會之決議以本公司名義及代表本公司簽署文件，並依董事會決議以及於董事會休會期間則依本公司之目標代表董事會為一切行為。董事長缺席時，依中華民國公司法第二百零八條之規定，由董事一人代為主席。

第 二十六 條：董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會中之一切事項代為行使表決權，但代理人以受一人委託為限。另董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第 二十七 條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。除董事全面改選之情況外，新董事之任期以補至原任之期限屆滿為止。

第 二十八 條：董事組織董事會，其職權如下：

營業計劃之擬定。

盈餘分配或虧損撥補之擬定。

資本增減之擬定。

修正公司章程之擬議。

重要契約之審定。

經理人之任免。

分公司、聯絡處之設置裁撤。

預算、決算之編定。

不動產買賣及投資其他事業之決定。

其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第 二十九 條：董事長及董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。

第五節 經 理 人

第 三十 條：本公司得設執行長一人、副執行長一人及經理人數人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條及相關法令規定辦理。

第 三十一 條：經理人承董事會命令依章程處理本公司一切業務並就該業務有簽名之權，暨任免不屬於本章程第二十七條第六款規定之職員。

第六節　會　　計

第 三十二 條：本公司之會計年度自每年元月一日起至十二月三十一日止。董事會應於每一會計年度終了辦理決算，造具下列各項表冊，依法提交股東常會請求承認：

營業報告書。

財務報表。

盈餘分派或虧損彌補之議案。

第 三十三 條：公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本公司稅前淨利，應提撥不低於5%為員工酬勞及不高於3 %為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象包括符合董事會所訂條件之控制或從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第 三十四 條：本公司盈餘分派或虧損彌補得於每半會計年度終了後為之。

每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後為之。本公司公開發行後分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告於股東會。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東股利之發放，其中現金股利於股利總額之 10%~100%，股票股利於股利總額之 0%~90%。

第七節　附　　則

第 三十五 條：本章程未定事項，悉依中華民國公司法辦理。

第 三十六 條：本章程訂立於民國九十七年四月一日。

第一次修訂於民國九十七年四月十八日。

第二次修訂於民國九十九年七月一日。

第三次修訂於民國一百零一年六月二十七日。

第四次修訂於民國一百零五年一月十二日。

第五次修訂於民國一百零七年九月四日。

第六次修訂於民國一百零八年三月十二日。

第七次修訂於民國一百零八年五月七日。

第八次修訂於民國一百零八年十一月十三日。

第九次修訂於民國一百零九年十一月二十四日。

第十次修訂於民國一百一零年七月二日。

力晶積成電子製造股份有限公司

修正條文對照表

修正前		修正後		修正理由
條次	條文	條次	條文	
第八條	本公司股票由代表公司之董事簽名或蓋章，載明公司法第一六二條所規定之各款事項，並依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。	第八條	刪除	配合本公司申請股票上市及實際需要修訂
第九條	本公司股票，應均為記名股票，並應標示各股東之真實姓名，其用法人名稱者，應記載各股東及（或）其代表人之真實姓名及住址於本公司之股東名簿。其為二人以上之股東所共有者，應推定一人為代表。	第九條	刪除	配合本公司申請股票上市及實際需要修訂
第九條之一	<略>。	第八條	<略>。	條次修改
第十條	<略>。	第九條	<略>。	條次修改
第十一條	<略>。	第十條	<略>。	條次修改
第十二條	<略>。	第十一條	<略>。	條次修改
第十三條	<略>。	第十二條	<略>。	條次修改
第十三條之一	<略>。	第十三條	<略>。	條次修改
		第十七條	本公司於召開股東會時，本公司應提供股東以書面或電子作為行使表決權方式，股東得以書面或電子方式行使表決權，其以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，相關事宜悉依法令規定辦理。	配合本公司申請股票上市及實際需要修訂
第十七條	<略>。	第十八條	<略>。	條次修改
第十八條	<略>。	第十九條	<略>。	條次修改
第十八條之一	<略>。	第十九條之一	<略>。	條次修改
第十九條	<略>。	第二十條	<略>。	條次修改
第十九條之一	<略>。	第二十條之一	<略>。	條次修改
第十九條之二	<略>。	第二十條之二	<略>。	條次修改
第二十條	<略>。	第二十一條	<略>。	條次修改
第二十一條	<略>。	第二十二條	<略>。	條次修改
第二十二條	<略>。	第二十三條	<略>。	條次修改
第二十三條	<略>。	第二十四條	<略>。	條次修改
第二十四條	<略>。	第二十五條	<略>。	條次修改
第二十五條	<略>。	第二十六條	<略>。	條次修改
第二十六條	<略>。	第二十七條	<略>。	條次修改
第二十七條	<略>。	第二十八條	<略>。	條次修改
第二十八條	<略>。	第二十九條	<略>。	條次修改
第二十九條	<略>。	第三十條	<略>。	條次修改

修正前		修正後		修正理由
條次	條文	條次	條文	
第三十條	**<略>。**	**第三十一條**	**<略>。**	條次修改
第三十一條	**<略>。**	**第三十二條**	**<略>。**	條次修改
第三十二條	**<略>。**	**第三十三條**	**<略>。**	條次修改
第三十三條	<略>。 每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後之。 <略>	**第三十四條**	<略>。 每半會計年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，預估保留應納稅捐及員工酬勞，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上半會計年度累計為未分配盈餘為股東紅利，由董事會擬具盈餘分派或虧損撥補案議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後為之。 <略>	配合本公司實際需要修訂及條次修改
第三十四條	**<略>。**	**第三十五條**	**<略>。**	條次修改
第三十五條	本章程訂立於民國九十七年四月一日。 第一次修訂於民國九十七年四月十八日。 第二次修訂於民國九十九年七月一日。 第三次修訂於民國一百零一年六月二十七日。 第四次修訂於民國一百零五年一月十二日。 第五次修訂於民國一百零七年九月四日。 第六次修訂於民國一百零八年三月十二日。 第七次修訂於民國一百零八年五月七日。 第八次修訂於民國一百零八年十一月十三日。 第九次修訂於民國一百零九年十一月二十四日。	**第三十六條**	本章程訂立於民國九十七年四月一日。 第一次修訂於民國九十七年四月十八日。 第二次修訂於民國九十九年七月一日。 第三次修訂於民國一百零一年六月二十七日。 第四次修訂於民國一百零五年一月十二日。 第五次修訂於民國一百零七年九月四日。 第六次修訂於民國一百零八年三月十二日。 第七次修訂於民國一百零八年五月七日。 第八次修訂於民國一百零八年十一月十三日。 第九次修訂於民國一百零九年十一月二十四日。 第十次修訂於民國一百一零年七月二日。	增列修訂日期及條次修改

【附件十六】

初次申請上市承諾事項

承諾書

本公司承諾下列事項：

承諾未來配合合肥晶合集成電路股份有限公司上市所出具之承諾事項，不得損及力晶積成電子製造股份有限公司之股東權益。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

承諾人：力晶科技股份有限公司

負責人：黃崇仁

中　華　民　國　1　1　0　年　9　月　8　日

承諾書

本公司承諾下列事項：

承諾於上市期間維持獨立董事席次占董事席次二分之一以上。

但如獨立董事因故解任，致人數不足董事席次二分之一以上者，應於最近一次股東會補選之；如獨立董事均解任時，本公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

本公司如於前項期間內補足獨立董事席次則不視為牴觸本條承諾事項。

此致

臺灣證券交易所股份有限公司

承諾人：力晶積成電子製造股份有限公司

負責人：黃崇仁

中　華　民　國　1　1　0　年　9　月　8　日

【附件十七】

承銷價格計算書

力晶積成電子製造股份有限公司

承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

(一)力晶積成電子製造股份有限公司(以下簡稱力積電或該公司)股票初次申請上市時之實收資本額為新臺幣 34,051,962,420 元，每股面額新臺幣 10 元整，分為 3,405,196,242 股。該公司擬於股票初次申請上市案經主管機關審查通過後，提出 130,000,000 股之股數辦理現金增資發行新股，預計股票上市掛牌時已發行股數為 3,535,196,242 股及實收資本額為 35,351,962,420 元。

(二)依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十一條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七之一條規定，公開發行公司初次申請股票上市時，至少應提出擬上市股份總額百分之十之股份，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。但應提出承銷之股數超過二千萬股以上者，得以不低於二千萬股之股數辦理公開銷售。另若公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數，但扣除之股數不得逾提出承銷總股數之百分之三十。

(三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度(上限)，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售；惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)該公司截至截至 2021 年 9 月 30 日止，記名股東人數為 322,596 人，內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數為 322,567 人，所持股份為 2,424,979,352 股，合計持股占發行股份總額 71.21%，已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第五條有關股權分散之標準。

(五)綜上所述，該公司依規定預計辦理現金增資發行新股 130,000,000 股，扣除依公司法規定保留百分之十五予員工優先認購之 19,500,000 股後，餘 110,500,000 股依據「證券交易法」第二十八之一條規定，經 2021 年 7 月 2 日股東會決議通過由原股東全數放棄認購以辦理上市前公開承銷作業，排除公司法第 267 條第三項原股東優先認購之適用。另本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售協議，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數百分之十五之額度範圍內，供本證券承銷商辦理過額配售及價格穩定作業，屆時主辦承銷商與該公司再依市場需求決定實際過額配售數量。

二、承銷價格

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1.承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

目前證券投資分析較常使用之股票價值評價方法主要包括市場法與成本法及收益法。各種方法皆有其優缺點，且採用方法不同，評估結果亦有所差異。其中，市場法包括本益比法(Price/Earnings ratio，P/E ratio)及股價淨值比法(Price/Book value ratio，P/B ratio)，皆係透過已公開的資訊，與整個市場、產業性

質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，進行公司價值評估，再依被評價公司與採樣公司之差異，進行折溢價調整，作成公司價值之結論；成本法主係為淨值法，並以帳面歷史成本作為公司價值之評估基礎；收益法主係以未來利益流量(如：現金流量…等)作為公司價值之評估基礎。茲將市場法、成本法及收益法等計算方式、優缺點與適用時機整理列示如下：

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比評估價值，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。	根據公司預估之獲利或現金流量，並以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，據以評估企業整體價值。
優點	1.最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2.所估算之價值與市場的股價較接近。 3.較能反映市場、研判多空氣氛及投資價值認定。 4.市場價格資料容易取得。	1.淨值係長期且穩定之指標。 2.當盈餘為負數時之替代評估方法。 3.市場價格資料容易取得。	1.評估資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同而影響。 3.反應企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。
缺點	1.盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3.企業盈餘為負數時不適用。	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。 3.不同種類資產需使用不同分析方法，且部分資產價值計算較為困難。	1.使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。
適用時機	1.企業生命週期屬成長型公司。 2.獲利型公司。	1.有鉅額資產但股價偏低的公司。 2.獲利波動幅度較大之公司。	1.適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。 2.虧損或營運衰退型公司。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

上述股價評價之各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦多有差異，其中因現金流量折現法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數之參考價值相對較低下，國內實務上較少採用此方法。因此，以市場法做為股價評價之基礎。

2.承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

(1)採樣同業之選擇

該公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶

圓代工，包含顯示高壓邏輯製程(High Voltage；主要應用於手機、平板、TV及電子紙等驅動 IC 及觸控驅動 IC 等產品)、電源管理晶片產品(Power IC)、分離式元件產品(Discrete)、CMOS 影像感測器產品(CIS；CMOS Image Sensor)、嵌入式非揮發性記憶體之晶圓代工服務；以及記憶體產品晶圓代工，包含動態隨機存取記憶體產品(DRAM)、快閃記憶體產品(NAND Flash、NOR Flash)之晶圓代工服務。

檢視目前上市櫃公司，選樣條件以同屬從事半導體晶圓代工服務或記憶體製造之公司，並參酌營業項目較為相近者，選取聯電(上市公司，股票代號：2303)、世界(上櫃公司，股票代號：5347)及華邦電(上市公司，股票代號：2344)作為採樣公司。其中，聯電主要係提供半導體晶圓代工之服務，專注於邏輯及特殊技術，包含電子行業的各項主要應用產品生產晶片；世界主要係提供半導體晶圓代工之服務，包含邏輯、混合訊號、高壓、超高壓、BCD、SOI、嵌入式非揮發性記憶體等製程，主要代工產品為 LCD 驅動 IC、電源管理 IC 及指紋辨識 IC 等；華邦電主要從事利基型記憶體 IC 設計、製造與銷售，產品包括利基型記憶體(Specialty DRAM)、行動記憶體(Mobile DRAM)以及編碼型快閃記憶體(Code Storage Flash Memory)等。

(2)市場法

A.該公司財務資料

單位：新臺幣千元；千股

項目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2020 年第四季至 2021 年第三季
本期淨利	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477	10,974,822
擬上市掛牌股數				3,535,196
每股盈餘(元)(註)	1.96	(0.75)	1.08	3.10

資料來源：該公司 2018~2020 年度經會計師查核簽證之財務報告及 2021 年度第三季經會計師核閱之財務報告。

註：每股盈餘及每股淨值係以擬上市掛牌股數追溯調整計算。

B.本益比法

單位：新臺幣元

公司	期間	每股盈餘(註 2)	平均收盤價	平均本益比(倍)
聯電(2303)	2021 年 8 月	3.62	59.57	16.46
	2021 年 9 月		66.16	18.28
	2021 年 10 月		59.53	16.44
世界(5347)	2021 年 8 月	4.98	139.95	28.10
	2021 年 9 月		158.18	31.76
	2021 年 10 月		144.4	29.00
華邦電(2344)	2021 年 8 月	1.90	31.09	16.36
	2021 年 9 月		28.69	15.10
	2021 年 10 月		25.39	13.36

半導體類股－上市	2021 年 8 月	—	—	25.33
	2021 年 9 月			24.02
	2021 年 10 月			23.73
半導體類股－上櫃	2021 年 8 月	—	—	25.69
	2021 年 9 月			24.51
	2021 年 10 月			25.35

資料來源：臺灣證券交易所及公開資訊觀測站。
註 1：平均本益比=平均收盤價/每股盈餘。
註 2：每股盈餘係以最近四季稅後純益除以 2021 年 6 月 30 日之股本計算
註 3：平均收盤價係以每日收盤價格平均計算。

該公司採樣同業及上市櫃「半導體」類股最近三個月(2021 年 8 月~2021 年 10 月)之平均本益比區間介於 13.36~31.76 倍之間，若以該公司最近四季之每股盈餘約為 3.10 元，按上述本益比區間計算，參考價格區間介於 41.42~98.46 元；並考量該公司經營績效、獲利情形、財務結構、產業未來發展前景及興櫃市場近期股價予以評估後，該公司此次上市與本證券承銷商議定之承銷價格每股新臺幣 49.88 元尚屬合理。

C.股價淨值比法

單位：新臺幣元

公司	期間	最近期財報每股淨值(註 2)	平均收盤價	平均股價淨值比(倍)
聯電(2303)	2021 年 8 月	19.33	59.57	3.08
	2021 年 9 月		66.16	3.42
	2021 年 10 月		59.53	3.08
世界(5347)	2021 年 8 月	17.33	139.95	8.08
	2021 年 9 月		158.18	9.13
	2021 年 10 月		144.40	8.33
華邦電(2344)	2021 年 8 月	19.14	31.09	1.62
	2021 年 9 月		28.69	1.50
	2021 年 10 月		25.39	1.33
半導體類股－上市	2021 年 8 月	—	—	5.82
	2021 年 9 月			5.52
	2021 年 10 月			5.55
半導體類股－上櫃	2021 年 8 月	—	—	5.11
	2021 年 9 月			4.88
	2021 年 10 月			5.1

資料來源：臺灣證券交易所及公開資訊觀測站。
註 1：平均股價淨值比=平均收盤價/每股淨值。
註 2：每股淨值係以 2021 年 6 月 30 日歸屬於母公司業主之權益除以之股本計算。
註 3：平均收盤價係以每日收盤價格平均計算。

採樣同業公司、上市大盤及半導體類股最近三個月之平均股價淨值比介於 1.33~9.13 倍，以該公司擬以掛牌股數 3,535,196 千股計算之每股淨值 14.75 元為基礎計算，價格區間約為 19.62~134.67 元；惟股價淨值比法使用

歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，故本證券承銷商不擬採用此法作為議定承銷價格參考之依據。

(3)成本法

成本法係為帳面價值法(Book Value Method)，帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包含債權人、普通股投資人及特別股投資人等。其中，股票投資者對公司之請求權價值係公司資產總和扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算依據，將忽略通貨膨脹因素且無法表達資產實際經濟價值，並深受財務報表採行之會計原則與方法影響，將可能低估成長型公司之企業價值，同時成本法使用上的限制有下列四項，因此國際上慣用成本法以評估企業價值者並不多見：

A.無法表達目前真正及外來之經濟貢獻值。

B.忽略技術經濟壽命。

C.技術廢舊及變革對於其所造成之風險無法預測。

D.成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，且該公司 2021 年 9 月 30 日經會計師核閱之歸屬母公司業主權益 52,157,308 千元及擬以掛牌股數 3,535,196 千股計算之每股淨值為 14.75 元，與興櫃市場交易價格差異甚大，且成本法並未考量公司成長性，較常用於評估傳統產業類股或衰退型公司，因此本證券承銷商不擬採用此種方法作為承銷價格訂定之參考依據。

(4)收益法–現金流量折現法

A.模型介紹

現金流量折現法之理論依據，係認為企業價值應等於未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，在多種理論模型中，以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映投資人之報酬率，其計算公式如下：

$$P_0 = V_E / N = (V_0 - V_D) / Shares$$

$$V_0 = \sum_{t=1}^{t=n} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^t} + \sum_{t=n+1}^{t=m} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{t-n}} + \frac{FCFF_{m+1}}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{m-n} \times (K3 - G)}$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - tax\ rate_t) + Dep_t \,\&\, Amo_t - Capital\ Exp_t - \Delta NWC_t$$

$$Ki = \frac{D}{A} \times Kd\,(1 - tax\ rate) + \frac{E}{A} \times Ke$$

$$Ke = Rf + \beta j\,(Rm - Rf)$$

P_0 ＝ 每股價值
V_0 ＝ 企業總體價值＝$V_E + V_D$＝股東權益價值＋負債價值
N ＝ 擬上市股數 3,535,196 千股
$FCFF_t$ ＝ 第 t 期之自由現金流量
Ki ＝ 加權平均資金成本 i=1,2,3
G ＝ 營業收入淨額成長率
n ＝ 5　第一階段之經營年限：2021 年度~2025 年度
m ＝ 10　第二階段之經營年限：2026 年度~2030 年度
$EBIT_t$ ＝ 第 t 期之息前稅前淨利
$tax\ rate_t$ ＝ 第 t 期之稅率
Dep_t & Amo_t ＝ 第 t 期之折舊與攤銷費用
$Capital\ Exp_t$ ＝ 第 t 期之資本支出
＝ 第 t 期之購置固定資產支出
ΔNWC_t ＝ 第 t 期之淨營運資金－第 t-1 期之淨營運資金
＝ (第 t 期之流動資產－不附息流動負債)－(第 t-1 期之流動資產－不附息流動負債)
D/A ＝ 附息負債資產比
E/A ＝ 權益資產比＝1－D/A
Kd ＝ 負債資金成本率
Ke ＝ 權益資金成本率
Rf ＝ 無風險利率
Rm ＝ 市場平均報酬率
βj ＝ 系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

B.股東權益資金成本率及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
t	t≦n n＝5	n+1≦t≦m n＝5,m＝10	m+1≦t m=10	依據該公司狀況分為三期間： 期間 I：2021~2025 年度 期間 II：2026~2030 年度 期間 III：2031 年度後(永續經營期)
D/A	41.7537%	40.8768%	40.0000%	預期該公司所屬產業持續成長，未來該公司將繼續穩定發展並持續擴廠，預計該公司除一般借款外，將會由資本市場募集資金，避免提高負債比率，假設公司營運穩定成長，隨著營業活動現金淨流入，營運資金尚為充裕，期間 III 能降至 40%。
E/A	58.2463%	59.1232%	60.0000%	同上。
Kd	1.5394%	1.5394%	1.5394%	因未來市場升息難以預測，且配合財務結構之假設，係以該公司 2018~2020 年度及 2021 年度第三季財務報告之平均借款利率預估未來之負債資金成本率。
$tax\ rate$	20.0000%	20.0000%	20.0000%	以財政部營利事業所得稅率 20%估計未來之稅率。
Rf	0.5484%	0.5484%	0.5484%	採用 2021 年 9 月 30 日櫃買中心 10 年以上之加權平均公債殖利率。預期 5 年以後之利率將持平。
Rm	9.4790%	9.4790%	9.4790%	係以 2009~2020 年度指數投資報酬率之幾何平均數估計

項目	期間Ⅰ	期間Ⅱ	期間Ⅲ	基本假設說明
βj	1.2996	1.1498	1.0000	採用半導體類指數對上市股票加權指數之平均風險係數估計該公司之系統風險；期間 I 係採用 2018 年度~2021 年第三季證券交易所營業日指數資料之風險係數；期間 III 預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為 1；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
Ke	12.1546%	10.8168%	9.4790%	依上述模型介紹之計算公式得出權益資金成本率。
Ki	7.7224%	7.0245%	6.3032%	依上述模型介紹之計算公式得出加權平均資金成本。

C.自由現金流量之參數設定及計算結果

(A)保守情境

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
G	9.0000%	6.1500%	3.3000%	期間 I 係 IC Insights 預估晶圓代工市場長期年成長率；期間 III 採用國際貨幣基金組織(IMF)發布之預測未來五年(2022~2026 年度)實質 GDP 成長率 3.30%；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
$EBIT_t$ $/Sales_t$	18.7447%	18.7447%	18.7447%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度)及 2021 年前三季平均息前稅前淨利率以估計未來之息前稅前淨利。
Dep_t/FA_t	1.9532%	1.9532%	1.9532%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度) 及 2021 年前三季平均折舊費用占折舊資產比率以估計未來之折舊攤銷費用。
$Capital$ $Exp_t/Sales_t$	34.1565%	3.0000%	2.0000%	期間 I 依 P5 廠建廠計畫預計投入金額占未來營收之比率，期間 II、期間 III 依未來資本支出計畫暫估。
ΔNWC_t $/Sales_t$	4.4142%	4.4142%	4.4142%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度) 2021 年前三季平均淨營運資金占營業收入比率以估計未來之淨營運資金。

(B)樂觀情境

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
G	16.0000%	9.6500%	3.3000%	期間 I 係 IC Insights 預估晶圓代工市場 2021 年成長率；期間 III 採用國際貨幣基金組織(IMF)發布之預測未來五年(2022~2026 年度)實質 GDP 成長率 3.30%；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
$EBIT_t$ $/Sales_t$	18.7447%	18.7447%	18.7447%	採用該公司過去三年度(2018~2020 年度)及 2021 年前三季平均息前稅前淨利率以估計未來之息前稅前淨利。

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
Dep_t / FA_t	1.9532%	1.9532%	1.9532%	採用該公司過去三年度(2018~2020年度) 及 2021 年前三季平均折舊費用占折舊資產比率以估計未來之折舊攤銷費用。
$Capital\ Exp_t/Sales_t$	34.1565%	3.0000%	2.0000%	期間 I 依 P5 廠建廠計畫預計投入金額占未來營收之比率，期間 II、期間 III 依未來資本支出計畫暫估。
$\Delta NWC_t /Sales_t$	4.4142%	4.4142%	4.4142%	採用該公司過去三年度(2018~2020年度) 2021 年前三季平均淨營運資金占營業收入比率以估計未來之淨營運資金。

D.每股價值之計算

(A)保守情境

$P_0 = (V_0 - V_D) / Shares$

= (189,457,924 千元－23,111,595 千元)/ 3,535,196 千股

= 47.05 元/股

(B)樂觀情境

$P_0 = (V_0 - V_D) / Shares$

= (306,709,257 千元－23,111,595 千元) / 3,535,196 千股

= 80.22 元/股

該公司依自由現金流量折現法保守情境及樂觀情境之參數假設及計算公式，計算其參考價格區間為 47.05~80.22 元。雖暫訂承銷價 49.88 元落於該價格區間內，惟此法主要係以未來各期創造現金流量之折現值合計認定為股東權益價值，然因未來之現金流量無法精確掌握，評價方法所使用之相關參數，如未來營收成長率、資本支出之假設多採用過去歷史經驗預估。在永續經營假設下，產業快速變化之特性使對未來之預估更具不確定性，較無法合理評估公司應有之價值，故對未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握，且相關參數之參考價值亦相對較為主觀，本次承銷價格訂定不擬採用此方法評估。

(二)該公司與已上市同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

茲就該公司與採樣同業公司聯電、世界及華邦電之財務狀況、獲利情形及本益比之比較分析列示如下：

1.財務狀況

單位：%；次；每股元

評估項目		年度 公司	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021年截至第三季
財務結構	負債占資產比率(%)	力積電	55.78	59.29	57.91	51.01
		聯　電	43.35	44.02	37.55	39.92
		世　界	21.81	30.99	32.32	41.11
		華邦電	33.48	39.07	43.99	40.97
		同　業	44.50	45.40	46.40	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	力積電	120.23	121.44	129.77	172.35
		聯　電	182.07	197.82	225.40	273.86
		世　界	472.74	236.34	238.59	213.17
		華邦電	151.61	153.20	163.65	187.02
		同　業	209.21	187.62	198.41	
償債能力	流動比率(%)	力積電	119.47	112.22	123.19	214.20
		聯　電	282.96	211.45	209.99	250.28
		世　界	358.91	190.60	194.35	210.62
		華邦電	227.86	214.42	186.58	222.06
		同　業	172.40	163.20	166.40	
	速動比率(%)	力積電	79.32	67.79	76.71	172.90
		聯　電	223.98	172.94	178.20	220.34
		世　界	309.13	160.81	165.96	180.42
		華邦電	161.63	155.43	131.07	168.36
		同　業	135.90	130.70	132.30	
	利息保障倍數(倍)	力積電	17.36	(3.51)	7.65	22.65
		聯　電	1.79	2.96	14.93	30.98
		世　界	0.00	179.74	114.75	277.54
		華邦電	33.46	5.36	4.47	36.06
		同　業	1,339.4	940.70	4,444.70	
經營能力	應收款項週轉率(次)(註 1)	力積電	8.50	6.10	7.86	7.99
		聯　電	6.59	5.89	6.56	6.77
		世　界	5.90	5.29	6.19	6.13
		華邦電	7.55	7.53	7.43	6.31
		同　業	4.90	5.00	5.40	
	存貨週轉率(次)(註 1)	力積電	5.39	5.01	4.88	4.60
		聯　電	7.04	6.36	6.23	6.12
		世　界	6.05	5.50	7.08	7.03
		華邦電	3.36	3.38	3.57	3.88
		同　業	7.20	7.10	7.10	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	力積電	1.32	0.82	0.97	1.27
		聯　電	0.80	0.92	1.25	1.59
		世　界	4.56	2.85	2.46	2.56
		華邦電	1.06	0.89	1.02	1.62
		同　業	3.10	2.70	2.70	
	總資產週轉率(次)	力積電	0.81	0.51	0.60	0.66
		聯　電	0.40	0.40	0.47	0.51

單位：%；次；每股元

評估項目		年度 公司	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021年截至第三季
		世　界	0.80	0.70	0.77	0.85
		華邦電	0.56	0.49	0.53	0.74
		同　業	0.90	0.90	0.90	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率。

註 1：應收帳款週轉率係以總額計算；存貨週轉率係以淨額計算。

(1)財務結構

A.負債占資產比率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之負債占資產比率分別為 55.78%、59.29%、57.91%及 51.01%，主係該公司基於營運策略考量，於 106 年購入竹南廠及生產設備以擴充產線，並向銀行申請聯貸案，使得負債比率整體偏高；2019 年度負債占資產比率較 2018 年度上升，主係竹南廠進行第二階段擴建專案，向銀行申請聯貸案所致；2020 年度負債占資產比率下降，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營運資金增加所致；2021 年第三季負債占資產比率較 2020 年度下降，主係該公司於 2021 年第一季辦理現金增資且收足股款，使得負債比率整體下降。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季負債占資產比率高於採樣公司及同業平均，主係因晶圓製造是一個高資本投入的行業，每年都會有資本支出計畫，在維護設備運作、既有產能去瓶頸化投資、或是建新廠，每家公司的產能建置狀況不同，所以每年度的不動產、廠房及設備投資金額也會有所差異，最近三年度及最近期該公司持續擴大營運，向銀行申請聯貸，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，故該等比率較差。惟隨該公司於 2021 年第一季辦理第一次現金增資，於 2021 年 6 月 11 日收足股款，並訂為現金增資基準日，2021 年第三季財務報告負債比率隨之下降，尚無重大異常之情事。

B.長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 120.23%、121.44%、129.77%及 172.35%，2019 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因擴建竹南廠增加長期銀行借款及租賃土地適用 IFRS 16 使用權資產之會計處理，租賃負債增加等使長期資金增加所致；2020 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、盈餘獲利使淨值提升所致；2021 年第三季長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利使淨值提升，且該公司為營運需求，向銀行增加借款所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，由於該公司積極擴建產能，不動產、廠房及設備金額自 2019 年躍升為 474 億元後，持續維持在 470 多億或近 470

億元，再加上未來銅鑼 P5 的建廠計畫，未來會隨著驗收進度，持續增加不動產、廠房及設備金額。2018~2020 年度及 2021 年第三季長期資金占不動產、廠房及設備比率雖低於採樣公司及同業平均，惟該等比率大於 100%，顯示該公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，且已逐年改善，2021 年 6 月已完成總籌資金額 120 億元的增資案，再加上未來上市前現增可募集金額，將可大幅提高該比率，拉近與同業間的距離，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司最近三年度及最近期之財務結構在營業規模逐漸成長及獲利挹注之下尚屬穩定，經評估應無重大異常之情事。

(2)償債能力

A.流動比率及速動比率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之流動比率分別為 119.47%、112.22%、123.19%及 214.20%，速動比率分別為 79.32%、67.79%、76.71 %及 172.90%，速動比率與流動比率變動趨勢相似，其 2019 年度流動比率及速動比率較 2018 年度低，主係該公司於 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入較 2018 年度下降 28.08%，帳上現金及應收帳款下降，使得流動資產及速動資產減少；2020 年度流動比率及速動比率較 2019 年度高，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，再加上當年度的資本支出規模較低，使得營業活動淨現金流入已足以支應投資活動及籌資活動的淨現金流出，故使流動資產項目中現金、應收帳款及存貨等皆較 2019 年度增加所致；2021 年第三季流動比率及速動比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營業收入增加，盈餘獲利使得營業活動淨現金流入，且該公司為營運需求，向銀行增加借款，另該公司於 2021 年第一季辦理現金增資並於第二季收足股款使得現金增加，綜上所述，帳上現金增加及應收帳款增加，使得流動資產及速動資產增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，2018~2020 年度該公司流動比率及速動比率低於採樣公司及同業平均，2021 年第三季則介於採樣公司間，主係因由於該公司當初受讓力晶公司 12 吋晶圓製造相關營業資產與負債，連帶亦承接當初銀行團的聯貸契約，所以仍有部分歷史包袱需要再還，隨著業績狀況轉佳，公司已一步一步調整好財務體質，相關比率也越來越好，惟流動比率大於 100%。且隨該公司於 2021 年第一季辦理第一次現金增資並於第二季收足股款，帳上現金增加，顯示該公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，且該等比率 2020 年度及 2021 年第三季已隨營收成長逐步提升，償債能力尚屬穩健，經評估其流動比率及速動比率之變化應無重大異常情事。

B.利息保障倍數

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之利息保障倍數分別為 17.36 倍、(3.51)倍、7.65 倍及 22.65 倍，2019 年度利息保障倍數較 2018 年低且為負數，主係該公司於 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，當年度營業收入相較 2018 年度下降，惟公司固定成本較高

使得營業毛利顯著下降，使 2019 年度處於虧損所致；2020 年度利息保障倍數增加，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利所致；2021 年第三季利息保障倍數增加，係因半導體需求熱絡，該公司產品銷售價格上升、銷售數量增加，營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，2019 年度華邦電及同業平均水準之利息保障倍數亦較 2018 年度下滑，惟該公司利息保障倍數皆低於採樣公司及同業平均水準，主係因 2019 年受貿易紛爭干擾，全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振，導致記憶體價格下跌，該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，受到記憶體價格下跌影響較鉅，且該公司驅動 IC 產品新舊技術平台轉換，綜上所述造成 2019 年度產生虧損，而使得利息保障倍數低；2018 及 2020 年度利息保障倍數均介於採樣公司及同業間。2021 年第三季利息保障倍數低於採樣公司，主係因 2021 年資本支出舉借長期借款，故造成利息費用增加，導致利息保障倍數增加幅度未若同業，惟該比率已自 2020 年度起逐年改善。整體而言，該公司之償債能力尚屬無虞，與同業相較尚無重大異常情事。

(3)經營能力

A.應收款項週轉率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之應收款項週轉率分別為 8.50 次、6.10 次、7.86 次及 7.99 次，2019 年度應收帳款週轉率下降，主係 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 2018 年度下降 28.08%，營業收入減少幅度高於平均應收款項總額減少幅度之故；2020 年應收款項週轉率上升，係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致；2021 年第三季應收款項週轉率略為上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長，較 2020 年度增加所致。整體而言，該公司之往來客戶多為國內外知名大廠，營運規模、財務狀況及長期往來信用良好，帳款品質穩定，且最近三年度及最近期並無實際發生呆帳損失，並無重大異常情事。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 2018 年度、2020 年度及 2021 年第三季應收款項週轉率均優於採樣同業及同業平均，2019 年度應收款項週轉率介於採樣同業之間，採樣同業間應收款項週轉情形差異主係因各公司之營運規模、收款政策及客戶組成不同所致，應無重大異常之情事。

B.存貨週轉率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之存貨週轉率分別為 5.39 次、5.01 次、4.88 次及 4.60 次，該公司係以接單式生產及計畫性生產兼具之生產方式安排生產排程及採購作業，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，存貨週轉率主要受到因訂單排程及客製化產品須提前備料，因而略有增減。2019 年度存貨週轉率較 2018 年度下降，主係 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 2018 年度下降，使相對的銷貨成本減少所致；而 2020 年度存貨週轉率下降，則主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，2020 年底為因

應 2021 年度訂單需求故增加原料備貨，2020 年存貨淨額提升所致；2021 年第三季存貨週轉率略為下降，係因半導體需求熱絡，為因應訂單需求故持續增加原料備貨，使平均存貨較 2020 年度平均存貨增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之存貨週轉率介於採樣公司及同業平均水準間，主係該公司記憶體產品之晶圓生產所需時間長於邏輯代工產品，故採樣同業相較之下低於邏輯代工同業如聯電與世界、高於記憶體同業華邦電，整體而言尚無重大異常情事。

C.不動產、廠房及設備週轉率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 1.32 次、0.82 次、0.97 次及 1.27 次，2019 年度不動產、廠房及設備週轉率較 2018 年度下降，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 2018 年度下降，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 2018 年增加所致；2020 年度不動產、廠房及設備週轉率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均不動產、廠房及設備之幅度所致；2021 年第三季不動產、廠房及設備週轉率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 2018 年度不動產、廠房及設備週轉率介於採樣公司及同業平均，2019 年度華邦電及同業平均水準之不動產、廠房及設備週轉率亦較 2018 年度下滑，惟該公司不動產、廠房及設備週轉率皆低於採樣公司及同業平均水準，主係因 2019 年受貿易紛爭干擾，全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振，導致記憶體價格下跌，該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，受到記憶體價格下跌影響較鉅，綜上所述造成 2019 年度營收下滑，而使得不動產、廠房及設備週轉率低；2020 年度及 2021 年第三季不動產、廠房及設備週轉率低於採樣公司及同業平均水準，主係因該公司持續擴大營運，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，故造成固定資產淨額較高，惟在營運持續暢旺下，該公司於 2020 年度不動產、廠房及設備週轉率逐漸提升。整體而言，該公司產品別與華邦電相似，同時具有邏輯產品及記憶體產品，使得 2018~2020 年度不動產、廠房及設備週轉率與華邦電相當，尚無重大異常之情事。

D.總資產週轉率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之總資產週轉率分別為 0.81 次、0.51 次、0.60 次及 0.66 次。2019 年度總資產週轉率皆較 2018 年度下降，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願致營業收入減少，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 2018 年增加；2020 年度因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均總資產之幅度所致；2021 年第三季總資產週轉率上升，係因半導體需求熱絡，該公司產品銷售價格上升、銷售數量增加，營收成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司總資產週轉率 2018~2020 年度

及 2021 年第三季皆介於採樣公司及同業平均，尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司之經營能力各項指標尚屬穩健，經評估尚無重大異常之情事。

2.獲利能力

評估項目		年度 公司	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021年截至第三季
獲利能力	權益報酬率(%)	力積電	23.37	(8.83)	12.07	30.90
		聯　電	1.26	2.96	12.27	21.14
		世　界	21.52	19.88	21.34	35.30
		華邦電	12.31	2.31	2.26	17.84
		同　業	14.10	10.40	14.90	
	營業利益占實收資本額比率(%)	力積電	247.77	(6.76)	18.50	49.15
		聯　電	4.67	3.99	17.72	36.57
		世　界	43.65	42.16	45.25	77.31
		華邦電	19.92	3.15	4.09	43.10
		同　業	註 1	註 1	註 1	
	稅前純益占實收資本額比率(%)	力積電	240.89	(8.42)	15.45	46.33
		聯　電	1.76	4.88	22.48	46.83
		世　界	45.59	44.90	46.17	78.55
		華邦電	21.09	4.40	4.55	42.44
		同　業	註 1	註 1	註 1	
	純益率(%)	力積電	13.85	(7.36)	8.33	21.57
		聯　電	1.75	4.14	15.37	25.41
		世　界	21.32	20.72	19.03	25.96
		華邦電	15.10	3.03	2.50	13.97
		同　業	8.10	6.40	9.00	
	每股稅後盈餘(元)(註 2)	力積電	2.56	(0.94)	1.23	3.07
		聯　電	0.58	0.82	2.42	3.26
		世　界	3.76	3.58	3.85	4.94
		華邦電	1.87	0.32	0.33	2.36
		同　業	註 1	註 1	註 1	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率。

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率及每股稅後盈餘。

註 2：每股稅後盈餘係以基本每股盈餘作揭露。

(1)權益報酬率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之權益報酬率分別為 23.37%、(8.83)%、12.07%及 30.90%，2019 年度股東權益報酬較 2018 年度低且為負數，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少且公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 2019 年度處於虧損所致；2020 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故權益報酬率由負轉正；2021 年第三季權益報酬率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓

代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司權益報酬率 2018 年度高於採樣公司及同業平均，2019 年度華邦電及同業平均水準之權益報酬率亦較 2018 年度下滑，惟該公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 2019 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 2019 年度產生虧損所致；2020 年度及 2021 年第三季介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈權益報酬率逐漸上升，顯示該公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

(2)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之營業利益占實收資本額比率分別為 247.77%、(6.76)%、18.50%及 49.15%；稅前純益占實收資本額比率分別為 240.89%、(8.42)%、15.45%及 46.33%，2018 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率較高，係因該公司於 2019 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組，收購力晶科技股份有限公司(以下簡稱力晶科)12 吋晶圓廠相關資產負債，並發行新股予力晶科作為取得對價，此交易係屬於共同控制下的組織重組，應追溯視為自始合併並重編比較期間之合併報告，於 2018 年度業經重編後的營業淨利及稅前純益係涵蓋受讓業務，然 2018 年度實收資本額則未改變仍為未併購前金額，致使該比率有較大差異；2019 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率為負數，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 2019 年度處於虧損所致；2020 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率皆由負轉正；2021 年第三季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司相較，該公司營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率，2018 年度高於採樣公司，2019 年度華邦電之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率亦較 2018 年度下滑，惟該公司低於採樣公司，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 2019 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 2019 年度產生虧損所致；2020 年度及 2021 年第三季介於採樣公司，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

(3)純益率及每股稅後盈餘

該公司 2018~2020 年度及 2021 年第三季之純益率分別為 13.85%、(7.36)%、8.33%及 21.57%；每股稅後盈餘分別為 2.56、(0.94)、1.23 及 3.07，

2019 年度純益率及每股稅後盈餘較 2018 年度低且為負數，係因 2019 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，致 2019 年度處於虧損；2020 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故純益率及每股稅後盈餘皆由負轉正；2021 年第三季純益率及每股稅後盈餘增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司純益率及每股稅後盈餘，2019 年度華邦電之純益率及每股稅後盈餘亦較 2018 年度下滑，惟該公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 2019 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 2019 年度產生虧損所致；2018 年度、2020 年度及 2021 年第三季之純益率及每股稅後盈餘介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

3.本益比

請參閱本評估報告「壹、二、(一)、2、(2)、B 本益比法」之評估說明。

(三)所議定之承銷價格若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本次承銷價格之議訂並無採取專家意見或鑑價報告，故不適用。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

該公司於 2021 年 12 月 9 日於興櫃市場掛牌，最近一個月（2021 年 10 月 22 日~2021 年 11 月 21 日）之月平均股價及成交量分別為 71.32 元及 445,690 千股。

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本證券承銷商經考量該公司之獲利能力、產業未來發展前景及初次上市股票流動性等因素，並參酌採樣同業公司及上市類股之本益比，以及該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據。復參酌該公司所處產業、市場地位、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本證券承銷商與該公司共同議定之。該公司初次上市前現金增資案採競價拍賣之承銷方式，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 8 條規定，設算向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日（2021 年 9 月 29 日~2021 年 11 月 10 日）其成交均價扣除無償配股（或減資除權）及除息後簡單算術平均數 65.27 元之七成（45.69 元）為上限，爰訂定最低承銷價格（競價拍賣底標）為 43 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；另依同法第 17 條規定，公開申購承銷價格以各得標單之價格及數量加權平均所得價格新台幣 63.52 元為之，惟該均價高於最低承銷價格之 1.16 倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣 49.88 元溢價發行，尚屬合理。

發行公司：力晶積成電子製造股份有限公司

負責人：黃崇仁

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

負責人：陳佩君

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

負責人：王濬智

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：黃進明

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：第一金證券股份有限公司

負責人：陳致全

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司

董　　事　　長：陳俊宏

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：台新綜合證券股份有限公司

負責人：郭嘉宏

中　華　民　國　　110.　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：臺灣土地銀行股份有限公司

代表人：董事長 謝娟娟

代理人：證券部經理 謝瑞員

中 華 民 國 110 年 11 月 22 日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

負責人：謝　政　雄

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

協辦證券承銷商：彰化商業銀行股份有限公司

負責人：凌忠嫄

中　華　民　國　110　年　11　月　22　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司現金增資發行新股辦理股票上市前公開承銷暨股票初次上市承銷價格計算書使用)

【附件十八】

股票初次上市證券承銷商評估報告

力晶積成電子製造股份有限公司

股票初次上市
證券承銷商評估報告

主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司

協辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

協辦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

協辦證券承銷商：第一金證券股份有限公司

協辦證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

力晶積成電子製造股份有限公司
發行人之產業、營運及其他重要風險

一、產業風險

(一)同業競爭壓力增加

近年半導體產業主要支撐力道來自於行動裝置、5G、AI 等產品，各相關晶圓代工廠亦受惠，引起業界關注。而近年中國政府致力於半導體產業扶植，以打造產業鏈一條龍為目標，積極投入設備及廣納人才。在全球代工產能供給增加的情況下，可能會面臨與同業競爭壓力。

因應對策

該公司及其子公司專注於晶圓代工業務，以世界級同步的技術，搭配國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的代工服務，以共創事業高峰。至今已陸續引進不同的代工客戶，客戶的產品可應用的範圍涵蓋了 3C 應用領域－電腦、無線通訊、消費性電子及車用電子等。

同時藉由擴大與全球產官學研究機構共同進行相關製程技術開發，以期提早掌握前瞻技術，有效縮短研發時程，降低專利與技術移轉成本。該公司及其子公司持續提供更優質的服務、產品及多元代工模式，以持續深化與客戶良好關係，為該公司及其子公司最佳的因應之道。透過 12 吋廠與 8 吋廠整合，提供客戶更完整的產品線及更完善的服務品質。

二、營運風險

(一)產能擴充之可能風險

因 12 吋代工客戶產能需求持續攀升，該公司及其子公司近期之 12 吋產能無法滿足客戶需求。為滿足中長期營運規劃。為滿足中長期營運規劃，該公司及其子公司在充分評估後，已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構 12 吋生產基地。惟因需求預測會隨著市場環境變化而產生顯著的改變，當需求減少時，已添購的機器設備及增聘的人員等將造成對該公司及其子公司財務表現產生負面的影響。

因應對策

該公司及其子公司會持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，若市場需求不如預期時，會及時調整其產能計劃，以降低對於公司財務表現的負面影響，且該公司及其子公司相關投資計畫尚在規劃中，原則以分期、分階段，以公司財務可負擔，最小風險下擴充廠房及產能，同時兼顧公司穩健成長與滿足客戶產能需求。

該公司及其子公司亦將擴廠設備風險轉嫁給客戶共同承擔，對上游 IC 設計業者

來說，即使本身公司設計具有競爭力，但沒有配合製造的產能也無濟於事，因此未來五年，晶圓代工產能將成為兵家必爭之地，而客戶端爭搶產能動作更加積極。目前該公司及其子公司與部分客戶間採取 Consign 的模式，由客戶購買機器設備租予該公司，再由該公司及其子公司代工產出產品，客戶可確保後續晶圓取得無虞，該公司及其子公司也能降低購買大量設備後需求減緩的風險。

(二)有關智慧財產權之風險

該公司及其子公司係以自行研發的製程技術、營業秘密及相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，然而尚無法保證營業秘密及相關 know-how 不被竊取或仿效，若發生此情事，將導致該公司及其子公司營收減少之可能性，也有可能在不知情的情況下侵害到他公司的智慧財產權，若有相關之訴訟可能導致該公司及其子公司有無法製造特定產品的風險。

因應對策

該公司及其子公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益損失的可能性。包含積極主張及保護該公司及其子公司所屬之智慧財產權，對於研發成功之產品基於智慧財產權，皆有申請專利保護。該公司及其子公司設有智權室防止製程中有侵害他人智慧財產權之情事，另外對於使用到的專利，皆有取得其他公司的授權，避免有侵權的風險。

三、其他重要風險

請詳評估報告「貳、二、發行公司營運風險」說明。

綜上所述，該公司及其子公司之產業、營運及其他重要風險三方面，分別予以評估其各項可能風險之因應措施，該公司及其子公司已具備因應相關風險之能力，各項因應措施尚屬妥適，應可有效降低相關風險

目　錄

壹、評估報告總評.....1
一、承銷總股數說明.....1
二、承銷價格.....2
三、承銷風險因素.....18
四、綜合具體結論.....19
貳、產業狀況及營運風險.....22
一、發行公司所屬行業之營運風險.....22
二、發行公司營運風險.....29
參、業務狀況.....135
一、營業概況.....135
二、存貨概況.....150
三、最近期及最近三個會計年度之業績概況.....157
肆、財務狀況.....171
一、列表並說明最近期及最近三個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力.....171
二、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之最近期及最近三個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響.....183
三、列明申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性.....188
四、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之轉投資事業.....193
五、承銷商依臺灣證券交易所股份有限公司「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條規定實地輔導發行公司之重要子公司者，應列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見.....198
六、評估發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於發行公司股票上市後對財務報表可能之影響.....199
七、公營事業申請股票上市時，其檢送之財務報告有未經會計師簽證者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見。.....200
八、金融事業申請股票上市，應列明其備抵提列情形，並評估其是否足額。.....200
九、承銷商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響.....200
伍、承銷商得視發行公司所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行公司目前營運狀況及未來發展，進行比較分析，並本獨立公正立場出具審查意見，俾利評估.....200

陸、法令之遵循及對本國發行公司營運影響由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素：.....201
一、發行公司是否違反相關法令規章.....201
二、董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使.....201
三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權.....202
四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件.....202
五、重大勞資糾紛或污染環境事件.....203
六、是否遇有證券交易法第156條第1項第1款至第3款所列之情事。.....203
柒、列明本國發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見;列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見。.....204
一、列明本國發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見.....204
二、列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見。.....204
捌、評估是否符合特定行業或組織型態公司之上市規定.....206
玖、評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形.....213
拾、對上列各項目有關證券承銷商評估報告完成日起，截至股票上市契約生效日之前一日止之期後事項，應隨時加以更新說明與評估；於股票上市用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，亦應加以更新說明與評估。.....213
拾壹、以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市者，承銷商應就被控股公司或其子公司之所營事業性質，依第四、五、六、八、九、十一及十二條等規定進行評估，出具各被控股公司或子公司之審查意見，再憑以出具綜合彙總意見。.....213
拾貳、本國上市(櫃)公司之海外子公司申請其股票第一上市者，承銷商應評估本國上市(櫃)公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施。.....213
拾參、其他補充揭露事項.....213

附件、依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之承銷商審查意見

壹、評估報告總評

一、承銷總股數說明

(一)力晶積成電子製造股份有限公司(以下簡稱力積電或該公司)股票初次申請上市時之實收資本額為新臺幣 34,051,962,420 元，每股面額新臺幣 10 元整，分為 3,405,196,242 股。該公司擬於股票初次申請上市案經主管機關審查通過後，提出 200,000,000 股之股數辦理現金增資發行新股，該次發行將全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，預計股票上市掛牌時已發行股數為 3,605,196,242 股及實收資本額為 36,051,962,420 元。

(二)依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十一條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七之一條規定，公開發行公司初次申請股票上市時，至少應提出擬上市股份總額百分之十之股份，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。但應提出承銷之股數超過二仟萬股以上者，得以不低於二仟萬股之股數辦理公開銷售。另若公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數，但扣除之股數不得逾提出承銷總股數之百分之三十。

(三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度(上限)，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售；惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)該公司截至 110 年 6 月 30 日止，記名股東人數共計 309,660 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東為 309,630 人，其所持有股份合計為 2,424,111,481 股，占已發行股份總額之 71.19%，已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第四條有關股權分散之標準。

(五)綜上所述，該公司依規定預計辦理現金增資發行新股 200,000,000 股，扣除依公司法規定保留百分之十五予員工優先認購之 30,000,000 股後，餘 170,000,000 股依據「證券交易法」第二十八之一條規定，經 110 年 7 月 2 日股東會決議通過由原股東全數放棄認購以辦理上市前公開承銷作業，排除公司法第 267 條第三項原股東優先認購之適用。另依證券商業同業公會中證商電字 1080005531 號函，大型無獲利事業(多元上市)、科技事業暨文創事業上市案，承銷金額達 20 億元以上，得採詢價圈購辦理承銷並引進基石投資人，本證券承銷商將評估資本市場後決定承銷方式。另本證券承銷商已與該公司簽訂過額配售協議，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數百分之十五之額度範圍內，供本證券承銷商辦理過額配售及價格穩定作業，屆時主辦承銷商與該公司再依市場需求決定實際過額配售數量。

二、承銷價格

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1.承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

目前證券投資分析較常使用之股票價值評價方法主要包括市場法與成本法及收益法。各種方法皆有其優缺點，且採用方法不同，評估結果亦有所差異。其中，市場法包括本益比法(Price/Earnings ratio，P/E ratio)及股價淨值比法(Price/Book value ratio，P/B ratio)，皆係透過已公開的資訊，與整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，進行公司價值評估，再依被評價公司與採樣公司之差異，進行折溢價調整，作成公司價值之結論；成本法主係為淨值法，並以帳面歷史成本作為公司價值之評估基礎；收益法主係以未來利益流量(如：現金流量…等)作為公司價值之評估基礎。茲將市場法、成本法及收益法等計算方式、優缺點與適用時機整理列示如下：

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比評估價值，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價或折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。	根據公司預估之獲利或現金流量，並以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，據以評估企業整體價值。
優點	1.最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2.所估算之價值與市場的股價較接近。 3.較能反映市場、研判多空氣氛及投資價值認定。 4.市場價格資料容易取得。	1.淨值係長期且穩定之指標。 2.當盈餘為負數時之替代評估方法。 3.市場價格資料容易取得。	1.評估資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同關鍵變數的預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同而影響。 3.反應企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
缺點	1.盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。 3.企業盈餘為負數時不適用。	1.帳面價值受會計方法之選擇所影響。 2.即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。 3.不同種類資產需使用不同分析方法，且部分資產價值計算較為困難。	1.使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3.預測期間較長。
適用時機	1.企業生命週期屬成長型公司。 2.獲利型公司。	1.有鉅額資產但股價偏低的公司。 2.獲利波動幅度較大之公司。	1.適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。 2.虧損或營運衰退型公司。	1.當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

上述股價評價之各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦多有差異，其中因現金流量折現法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數之參考價值相對較低下，國內實務上較少採用此方法。因此，以市場法做為股價評價之基礎。

2.承銷價格訂定與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

(1)採樣同業之選擇

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工，包含顯示高壓邏輯製程(High Voltage；主要應用於手機、平板、TV 及電子紙等驅動 IC 及觸控驅動 IC 等產品)、電源管理晶片產品(Power IC)、分離式元件產品(Discrete)、CMOS 影像感測器產品(CIS；CMOS Image Sensor)、嵌入式非揮發性記憶體之晶圓代工服務；以及記憶體產品晶圓代工，包含動態隨機存取記憶體產品(DRAM)、快閃記憶體產品(NAND Flash、NOR Flash)之晶圓代工服務。

檢視目前上市櫃公司，選樣條件以同屬從事半導體晶圓代工服務或記憶體製造之公司，並參酌營業項目較為相近者，選取聯電(上市公司，股票代號：2303)、世界(上櫃公司，股票代號：5347)及華邦電(上市公司，股票代號：2344)作為採樣公司。其中，聯電主要係提供半導體晶圓代工之服務，專注於邏輯及特殊技術，包含電子行業的各項主要應用產品生產晶片；世界主要係提供半導體晶圓代工之服務，包含邏輯、混合訊號、高壓、超高壓、BCD、SOI、嵌入式非揮發性記憶體等製程，主要代工產品為 LCD 驅動 IC、電源管理 IC 及指紋辨識 IC 等；華邦電主要從事利基型記憶體 IC 設計、製造與銷售，產品包括利基型記憶體(Specialty DRAM)、行動記憶體(Mobile DRAM)以及編碼型快閃記憶體(Code Storage Flash

Memory)等。

(2)市場法

A.該公司財務資料

單位：新臺幣仟元；仟股

項目	107 年度	108 年度	109 年度	109 年第二季至 110 年第一季
本期淨利	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477	4,675,254
擬上市掛牌股數				3,605,196
每股盈餘(元)(註)	1.92	(0.73)	1.06	1.30

資料來源：該公司及其子公司 107~109 年度經會計師查核簽證之財務報告及 110 年度第一季經會計師核閱之財務報告。
註：每股盈餘及每股淨值係以擬上市掛牌股數追溯調整計算。

B.本益比法

單位：新臺幣元

公司	期間	每股盈餘(註 2)	平均收盤價	平均本益比(倍)
聯電(2303)	110 年 4 月	3.01	54.76	18.19
	110 年 5 月		49.94	16.59
	110 年 6 月		52.48	17.44
世界(5347)	110 年 4 月	4.30	115.26	26.80
	110 年 5 月		110.86	25.78
	110 年 6 月		117.88	27.41
華邦電(2344)	110 年 4 月	0.75	34.64	46.19
	110 年 5 月		30.69	40.92
	110 年 6 月		34.06	45.41
半導體類股－上市	110 年 4 月	—	—	29.91
	110 年 5 月			26.84
	110 年 6 月			26.81
半導體類股－上櫃	110 年 4 月	—	—	27.54
	110 年 5 月			25.05
	110 年 6 月			27.08

資料來源：臺灣證券交易所及公開資訊觀測站。
註 1：平均本益比=平均收盤價/每股盈餘。
註 2：每股盈餘係以最近四季稅後純益除以 110 年 3 月 31 日之股本計算
註 3：平均收盤價係以每日收盤價格平均計算。

該公司採樣同業及上市櫃「半導體」類股最近三個月(110 年 4 月~110 年 6 月)之平均本益比區間介於 16.59~46.19 倍之間，若以該公司最近四季之每股盈餘約為 1.30 元，按上述本益比區間計算，參考價格區間介於 21.57~60.05 元；

並考量該公司經營績效、獲利情形、財務結構、產業未來發展前景、興櫃市場近期股價及流動性不足之風險予以折價後，該公司此次上市與本證券承銷商議定之暫定承銷價格每股新臺幣 50 元尚屬合理。

C.股價淨值比法

單位：新臺幣元

公司	期間	最近期財報每股淨值(註 2)	平均收盤價	平均股價淨值比(倍)
聯電(2303)	110 年 4 月	20.09	54.76	2.73
	110 年 5 月		49.94	2.49
	110 年 6 月		52.48	2.61
世界(5347)	110 年 4 月	19.46	115.26	5.92
	110 年 5 月		110.86	5.70
	110 年 6 月		117.88	6.06
華邦電(2344)	110 年 4 月	17.12	34.64	2.02
	110 年 5 月		30.69	1.79
	110 年 6 月		34.06	1.99
半導體類股－上市	110 年 4 月	－	－	6.15
	110 年 5 月			5.71
	110 年 6 月			5.70
半導體類股－上櫃	110 年 4 月	－	－	4.89
	110 年 5 月			4.44
	110 年 6 月			4.80

資料來源：臺灣證券交易所及公開資訊觀測站。
註 1：平均股價淨值比=平均收盤價/每股淨值。
註 2：每股淨值係以 110 年 3 月 31 日歸屬於母公司業主之權益除以之股本計算。
註 3：平均收盤價係以每日收盤價格平均計算。

採樣同業公司、上市大盤及半導體類股最近三個月之平均股價淨值比介於 1.79~6.15 倍，以該公司擬以掛牌股數 3,605,196 仟股計算之每股淨值 9.42 元為基礎計算，價格區間約為 16.86~57.93 元；惟股價淨值比法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，故本證券承銷商不擬採用此法作為議定承銷價格參考之依據。

(3)成本法

成本法係為帳面價值法(Book Value Method)，帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包含債權人、普通股投資人及特別股投資人等。其中，股票投資者對公司之請求權價值係公司資產總和扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算依據，將忽略通貨膨脹因素且無法表達資產實際經濟價值，並深受財務報表採行之會計原則與方法影響，將可能低估成長型公司之企業

價值，同時成本法使用上的限制有下列四項，因此國際上慣用成本法以評估企業價值者並不多見：

A.無法表達目前真正及外來之經濟貢獻值。

B.忽略技術經濟壽命。

C.技術廢舊及變革對於其所造成之風險無法預測。

D.成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，且該公司 110 年 3 月 31 日經會計師核閱之歸屬母公司業主權益 33,958,594 仟元及擬以掛牌股數 3,605,196 仟股計算之每股淨值為 9.42 元，與興櫃市場交易價格差異甚大，且成本法並未考量公司成長性，較常用於評估傳統產業類股或衰退型公司，因此本證券承銷商不擬採用此種方法作為承銷價格訂定之參考依據。

(4)收益法－現金流量折現法

A.模型介紹

現金流量折現法之理論依據，係認為企業價值應等於未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，在多種理論模型中，以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映投資人之報酬率，其計算公式如下：

$$P_0 = V_E / N = (V_0 - V_D) / Shares$$

$$V_0 = \sum_{t=1}^{t=n} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^t} + \sum_{t=n+1}^{t=m} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{t-n}} + \frac{FCFF_{m+1}}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{m-n} \times (K3 - G)}$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - tax\ rate_t) + Dep_t \,\&\, Amo_t - Capital\ Exp_t - \triangle NWC_t$$

$$Ki = \frac{D}{A} \times Kd\,(1 - tax\ rate) + \frac{E}{A} \times Ke$$

$$Ke = Rf + \beta j\,(Rm - Rf)$$

P_0 ＝ 每股價值
V_0 ＝ 企業總體價值＝$V_E + V_D$＝股東權益價值＋負債價值
N ＝ 擬上市股數 3,605,196 仟股
$FCFF_t$ ＝ 第 t 期之自由現金流量
Ki ＝ 加權平均資金成本 i＝1,2,3
G ＝ 營業收入淨額成長率

n ＝ 5　第一階段之經營年限：110 年度~114 年度
m ＝ 10　第二階段之經營年限：115 年度~119 年度
$EBIT_t$ ＝ 第 t 期之息前稅前淨利
$tax\ rate_t$ ＝ 第 t 期之稅率
Dep_t & Amo_t ＝ 第 t 期之折舊與攤銷費用
$Capital\ Exp_t$ ＝ 第 t 期之資本支出
＝ 第 t 期之購置固定資產支出
$\triangle NWC_t$ ＝ 第 t 期之淨營運資金－第 t-1 期之淨營運資金
＝ (第 t 期之流動資產－不附息流動負債)－(第 t-1 期之流動資產－不附息流動負債)
D/A ＝ 孳息負債/(孳息負債+股東權益)
E/A ＝ 權益資產比＝1－D/A
Kd ＝ 負債資金成本率
Ke ＝ 權益資金成本率
Rf ＝ 無風險利率
Rm ＝ 市場平均報酬率
βj ＝ 系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

B.股東權益資金成本率及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間Ⅰ	期間Ⅱ	期間Ⅲ	基本假設說明
t	t≦n n＝5	n+1≦t≦m n＝5,m＝10	m+1≦t m=10	依據該公司狀況分為三期間： 期間Ⅰ：110~114 年度 期間Ⅱ：115~119 年度 期間Ⅲ：120 年度後(永續經營期)
D/A	43.0478%	41.5239%	40.0000%	預期該公司所屬產業持續成長，未來該公司將繼續穩定發展並持續擴廠，預計該公司除一般借款外，將會由資本市場募集資金，避免提高負債比率，假設公司營運穩定成長，隨著營業活動現金淨流入，營運資金尚為充裕，期間Ⅲ能降至 40%。
E/A	56.9522%	58.4761%	60.0000%	同上。
Kd	1.5531%	1.5531%	1.5531%	因未來市場升息難以預測，且配合財務結構之假設，係以該公司 107~109 年度及 110 年度第一季財務報告之平均借款利率預估未來之負債資金成本率。
$tax\ rate$	20.0000%	20.0000%	20.0000%	以財政部營利事業所得稅率 20%估計未來之稅率。
Rf	0.5901%	0.5901%	0.5901%	採用 110 年 6 月 30 日櫃買中心 10 年以上之加權平均公債殖利率。預期 5 年以後之利率將持平。
Rm	12.5882%	12.5882%	12.5882%	係以 2011~2020 年度指數投資報酬率之幾何平均數估計。
βj	1.3468	1.1734	1.0000	採用半導體類指數對上市股票加權指數之平均風險係數估計該公司之系統風險；期間Ⅰ係採用 107 年度~110 年第一季證券交易所營業日指數資料之風險係數；期間Ⅲ預期永續經營期之系統風險將逐步貼近市場之系統風險，故假設為 1；期間Ⅱ則取期間Ⅰ與期間Ⅲ之平均值。
Ke	22.4879%	19.6686%	16.8492%	依上述模型介紹之計算公式得出權益資金成本率。
Ki	13.4759%	12.1463%	10.7308%	依上述模型介紹之計算公式得出加權平均資金成本。

C.自由現金流量之參數設定及計算結果

(A)保守情境

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
G	16.0000%	9.6500%	3.3000%	期間 I 係晶圓代工市場年預估成長率；期間 III 採用國際貨幣基金組織(IMF)發布之預測未來五年(111~115 年度)實質 GDP 成長率 3.30%；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
$EBIT_t$ /$Sales_t$	15.6513%	15.6513%	15.6513%	採用該公司過去三年度(107~109 年度)及 110 年第一季平均息前稅前淨利率以估計未來之息前稅前淨利。
Dep_t / FA_t	1.6526%	1.6526%	1.6526%	採用該公司過去三年度(107~109 年度) 及 110 年第一季平均折舊費用占折舊資產比率以估計未來之折舊攤銷費用。
Capital Exp_t/$Sales_t$	8.6424%	6.4818%	4.3212%	期間 I 依 P5 廠建廠計畫預計投入金額占未來營收之比率，期間 III 依未來建廠計畫暫估 50%，期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
ΔNWC_t /$Sales_t$	3.8470%	3.8470%	3.8470%	採用該公司過去三年度(107~109 年度) 110 年第一季平均淨營運資金占營業收入比率以估計未來之淨營運資金。

(B)樂觀情境

項目	期間 I	期間 II	期間 III	基本假設說明
G	27.2654%	15.2827%	3.3000%	期間 I 係該公司仍處於穩健獲利階段，預期上市後，營業收入將可穩健成長，惟 108 年度受中美貿易影響半導體產業之不確定性因素繼續蔓延營收衰退，排除此因素使用 109 年度營業收入淨額成長率；期間 III 採用國際貨幣基金組織(IMF)發布之預測未來五年(111~115 年度)實質 GDP 成長率 3.30%；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。
$EBIT_t$ /$Sales_t$	15.6513%	15.6513%	15.6513%	採用該公司過去三年度(107~109 年度)及 110 年第一季平均息前稅前淨利率以估計未來之息前稅前淨利。
Dep_t / FA_t	1.6526%	1.6526%	1.6526%	採用該公司過去三年度(107~109 年度) 及 110 年第一季平均折舊費用占折舊資產比率以估計未來之折舊攤銷費用。
Capital Exp_t/$Sales_t$	8.6424%	6.4818%	4.3212%	期間 I 依 P5 廠建廠計畫預計投入金額占未來營收之比率，期間 III 依未來建廠計畫暫估 50%，期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平均值。。
ΔNWC_t /$Sales_t$	3.8470%	3.8470%	3.8470%	採用該公司過去三年度(107~109 年度) 110 年第一季平均淨營運資金占營業收入比率以估計未來之淨營運資金。

D.每股價值之計算

(A)保守情境

$P_0 = (V_0 - V_D) / Shares$

= (117,639,217 仟元－25,667,885 仟元)/3,605,196 仟股

= 25.51 元/股

(B)樂觀情境

$P_0 = (V_0 - V_D) / Shares$

= (213,215,183 仟元－25,667,885 仟元) / 3,605,196 仟股

= 52.02 元/股

該公司依自由現金流量折現法保守情境及樂觀情境之參數假設及計算公式，計算其參考價格區間為 25.51~52.02 元。雖暫訂承銷價 50 元落於該價格區間內，惟此法主要係以未來各期創造現金流量之折現值合計認定為股東權益價值，然因未來之現金流量無法精確掌握，評價方法所使用之相關參數，如未來營收成長率、資本支出之假設多採用過去歷史經驗預估。在永續經營假設下，產業快速變化之特性使對未來之預估更具不確定性，較無法合理評估公司應有之價值，故對未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握，且相關參數之參考價值亦相對較為主觀，本次承銷價格訂定不擬採用此方法評估。

(二)該公司與已上市同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

茲就該公司與採樣同業公司聯電、世界及華邦電之財務狀況、獲利情形及本益比之比較分析列示如下：

1.財務狀況

單位：%；次；每股元

評估項目		年度／公司	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至 3 月 31 日
財務結構	負債占資產比率(%)	力積電	55.78	59.29	57.91	58.52
		聯　電	43.35	44.02	37.55	36.67
		世　界	21.81	30.99	32.32	32.82
		華邦電	33.48	39.07	43.99	42.58
		同　業	44.5	45.4	註 1	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	力積電	120.23	121.44	129.77	137.27
		聯　電	182.07	197.82	225.40	249.73
		世　界	472.74	236.34	238.59	249.73
		華邦電	151.61	153.20	163.65	171.02
		同　業	209.21	187.62	註 1	
償債能力	流動比率(%)	力積電	119.47	112.22	123.19	140.95
		聯　電	282.96	211.45	209.99	228.04
		世　界	358.91	190.60	194.35	217.85
		華邦電	227.86	214.42	186.58	201.98
		同　業	172.4	163.20	註 1	

單位：%；次；每股元

評估項目		年度 公司	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至 3 月 31 日
	速動比率(%)	力積電	79.32	67.79	76.71	93.42
		聯　電	223.98	172.94	178.20	196.68
		世　界	309.13	160.81	165.96	188.41
		華邦電	161.63	155.43	131.07	144.50
		同　業	135.90	130.70	註 1	
	利息保障倍數(倍)	力積電	17.36	(3.51)	7.65	13.79
		聯　電	1.79	2.96	14.93	29.27
		世　界	0.00	179.74	114.75	206.41
		華邦電	33.46	5.36	4.47	18.15
		同　業	1,339.4	940.70	註 1	
經營能力	應收款項週轉率(次)(註 2)	力積電	8.50	6.10	7.86	7.80
		聯　電	6.59	5.89	6.56	6.62
		世　界	5.90	5.29	6.19	6.11
		華邦電	7.55	7.53	7.43	8.07
		同　業	4.90	5.00	註 1	
	存貨週轉率(次)(註 2)	力積電	5.39	5.01	4.88	4.52
		聯　電	7.04	6.36	6.23	6.18
		世　界	6.05	5.50	7.08	7.08
		華邦電	3.36	3.38	3.57	3.72
		同　業	7.20	7.10	註 1	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	力積電	1.32	0.82	0.97	1.13
		聯　電	0.80	0.92	1.25	1.45
		世　界	4.56	2.85	2.46	2.65
		華邦電	1.06	0.89	1.02	1.40
		同　業	3.10	2.70	註 1	
	總資產週轉率(次)	力積電	0.81	0.51	0.60	0.66
		聯　電	0.40	0.40	0.47	0.49
		世　界	0.80	0.70	0.77	0.81
		華邦電	0.56	0.49	0.53	0.67
		同　業	0.90	0.90	註 1	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率。

註 1：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版該年度之主要行業財務比率。

註 2：應收帳款週轉率係以總額計算；存貨週轉率係以淨額計算。

(1)財務結構

A.負債占資產比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之負債占資產比率分別為 55.78%、59.29%、57.91%及 58.52%，主係該公司及其子公司基於營運策略考量，於 106 年購入竹南廠及生產設備以擴充產線，並向銀行申請聯貸案，使得負債比率整體偏高；108 年度負債占資產比率較 107 年度上升，主係竹南廠進行第二階段擴建專案，向銀行申請聯貸案所致；109 年度負債占資產比率下降，係因該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營運資金增加所致；110 年第一季負債占資產比率較 110 年度略微上升，主係該公司及其子公司為營運需求，向銀行增加借款所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季負債占資產比率高於採樣公司及同業平均。晶圓製造是一個高資本

投入的行業，每年都會有資本支出計畫，可能是在維護設備運作、既有產能去瓶頸化投資、或是建新廠，每家公司的產能建置狀況不同，所以每年度的不動產、廠房及設備投資金額也會有所差異，若是有新建廠的情形，通常需新舉債或耗用大筆自有資金，會使得負債比或流動比率變差。基本上可以取得不動產、廠房及設備金額與折舊費用的比例來判斷公司是否有新建廠或重大資本支出，若是比率低於 1，代表取得金額小於折舊費用，則代表該公司沒有積極擴增產能，反之，則可能有大規模投資。該公司及其子公司最近三年度及最近期取得不動產、廠房及設備金額與折舊費用的比例分別為 2.65、2.51、0.56 及 1.18 倍，除 109 年度低於 1 以外，其他年度皆高於 1，顯見該公司持續擴大營運，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，故該等比率較差。相較於同業，聯電的比率皆低於 1，華邦電及世界分別於 107 及 108 年度高於 2，其餘各其皆低於 2，顯見該公司及其子公司擴產態度較為積極。惟隨該公司於 110 年第一季辦理第一次現金增資，於 110 年 6 月 11 日收足股款，並訂為現金增資基準日，預計至第二季財報負債比率將可隨之下降，尚無重大異常之情事。

B.長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 120.23%、121.44%、129.77%及 137.27%，108 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因擴建竹南廠增加長期銀行借款及租賃土地適用 IFRS 16 使用權資產之會計處理，租賃負債增加等使長期資金增加所致；109 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、盈餘獲利使淨值提升所致；110 年第一季長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長、盈餘獲利使淨值提升，且該公司為營運需求，向銀行增加借款所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，由於該公司及其子公司積極擴建產能，不動產、廠房及設備金額自 108 年躍升為 474 億元後，持續維持在 470 多億或近 470 億元，再加上未來銅鑼 P5 的建廠計畫，未來會隨著驗收進度，持續增加不動產、廠房及設備金額。107~109 年度及 110 年第一季長期資金占不動產、廠房及設備比率雖低於採樣公司及同業平均，惟該等比率大於 100%，顯示該公司及其子公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，且已逐年改善，最近期已達 137.27%，與華邦電的 171.02%接近，110 年 6 月已完成總籌資金額 120 億元的增資案，再加上未來上市前現增可募集金額，將可大幅提高該比率，拉近與同業間的距離，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司及其子公司最近三年度及最近期之財務結構在營業規模逐漸成長及獲利挹注之下尚屬穩定，經評估應無重大異常之情事。

(2)償債能力

A.流動比率及速動比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之流動比率分別為 119.47%、112.22%、123.19%及 140.95%，速動比率分別為 79.32%、67.79%、76.71 %及 93.42%，速動比率與流動比率變動趨勢相似，其 108 年度流動比率及速動比率較 107 年度低，主係該公司及其子公司於 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入較 107 年度下降 28.08%，帳上現金及應收帳款下降，使得流動資產及速動資產減少；109 年度流動比率及速動比率較 108 年度高，係因該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，再加上當年度的資本支出規模較低，使得營業活動淨現金流入已足以支應投資活動及籌資活動的淨現金流出，故使流動資產項目中現金、應收帳款及存貨等皆較 108 年度增加所致；110 年第一季流動比率及速動比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營業收入增加，盈餘獲利使得營業活動淨現金流入，且該公司為營運需求，向銀行增加借款，綜上所述，帳上現金增加及應收帳款增加，使得流動資產及速動資產增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，107~109 年度及 110 年第一季該公司及子公司流動比率及速動比率雖低於採樣公司及同業平均，惟流動比率大於 100%，顯示該公司及其子公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，且該公司及其子公司的流動比率及速動比率除了 108 年度因為虧損使得該比率較前一年度下滑外，隨著營運狀況越來越好，比率已逐步提升。由於該公司當初受讓力晶公司 12 吋晶圓製造相關營業資產與負債，連帶亦承接當初銀行團的聯貸契約，所以仍有部分歷史包袱需要再還，隨著業績狀況轉佳，公司已一步一步調整好財務體質，相關比率也越來越好。與採樣公司及同業平均水準相較，107~109 年度及 110 年第一季該公司及子公司流動比率及速動比率雖低於採樣公司及同業平均，惟流動比率大於 100%，顯示該公司及其子公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，且該等比率 109 年隨營收成長逐步提升，顯見其償債能力尚屬穩健，經評估其流動比率之變化應無重大異常情事。

B.利息保障倍數

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之利息保障倍數分別為 17.36 倍、(3.51)倍、7.65 倍及 13.79 倍，108 年度利息保障倍數較 107 年低且為負數，主係該公司及其子公司於 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，當年度營業收入相較 107 年度下降，惟公司固

定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度利息保障倍數增加，係因該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利所致；110 年第一季利息保障倍數增加，係因半導體需求熱絡，該公司及其子公司產品銷售價格上升、銷售數量增加，營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，108 年度由於該公司虧損，故保障倍數為負值，低於採樣公司及同業平均水準，不過華邦電及同業平均水準之利息保障倍數亦較 107 年度下滑，實為整體產業趨勢，主係因 108 年受貿易紛爭干擾，全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振，導致記憶體價格下跌，該公司及其子公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，受到記憶體價格下跌影響較鉅，且該公司及其子公司驅動 IC 產品新舊技術平台轉換，綜上所述造成 108 年度產生虧損，而使得利息保障倍數低；107、109 年度利息保障倍數均介於採樣公司及同業間；110 年第一季利息保障倍數與華邦電相當。整體而言，該公司及其子公司之償債能力尚屬無虞，與同業相較尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及最近期之償債能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

(3)經營能力

A.應收款項週轉率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之應收款項週轉率分別為 8.50 次、6.10 次、7.86 次及 7.80 次，108 年度應收帳款週轉率下降，主係 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降 28.08%，營業收入減少幅度高於平均應收款項總額減少幅度之故；109 年應收款項週轉率上升，係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致；110 年第一季應收款項週轉率略為下降，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長使期末應收帳款增加，使平均應收帳款較 109 年度增加所致。整體而言，該公司及其子公司之往來客戶多為國內外知名大廠，營運規模、財務狀況及長期往來信用良好，帳款品質穩定，且最近三年度及最近期並無實際發生呆帳損失，並無重大異常情事。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司 107 及 109 年度應收款項週轉率均優於採樣同業，108 年度及 110 年第一季應收款項週轉率及收現天數均介於採樣同業之間，採樣同業間應收款項週轉情形差異主係因各公司之營運規模、收款政策及客戶組成不同所致，應無重大異常之情事。

B.存貨週轉率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之存貨週轉率分別為 5.39 次、5.01 次、4.88 次及 4.52 次，該公司及其子公司係以接單式生產及計畫性生產兼具之生產方式安排生產排程及採購作業，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，存貨週轉率主要受到因訂單排程及客製化產品須提前備料，因而略有增減。108 年度存貨週轉率較 107 年度下降，主係 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降，使相對的銷貨成本減少所致；而 109 年度存貨週轉率下降，則主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，109 年底為因應 110 年度訂單需求故增加原料備貨，109 年存貨淨額提升所致；110 年第一季存貨週轉率略為下降，係因半導體需求熱絡，為因應訂單需求故持續增加原料備貨，使平均存貨較 109 年度平均存貨增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之存貨週轉率介於採樣公司及同業平均水準間，整體而言尚無重大異常情事。

C.不動產、廠房及設備週轉率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 1.32 次、0.82 次、0.97 次及 1.13 次，108 年度不動產、廠房及設備週轉率較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 107 年增加所致；109 年度不動產、廠房及設備週轉率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均不動產、廠房及設備之幅度所致；110 年第一季不動產、廠房及設備週轉率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司 107 年度不動產、廠房及設備週轉率介於採樣公司及同業平均，108 年度華邦電及同業平均水準之不動產、廠房及設備週轉率亦較 107 年度下滑，惟該公司及其子公司不動產、廠房及設備週轉率皆低於採樣公司及同業平均水準，主係中美貿易影響半導體產業之不確定性因素繼續蔓延，邏輯產品終端客戶拉貨需求降低，加上記憶體市況不佳、單位售價(ASP)下跌等因素影響，致當年度營業收入相較 107 年度下降 28.08%，下滑幅度大於同業，而使得不動產、廠房及設備週轉率低；109 年度不動產、廠房及設備週轉率皆低於採樣公司及同業平均水準，惟在營運持續暢旺下，該公司及其子公司於 109 年度不動產、廠房及設備週轉率逐

漸提升；110 年第一季不動產、廠房及設備週轉率介於採樣公司及同業平均。整體而言，該公司及其子公司產品別與華邦電相似，同時具有邏輯產品及記憶體產品，使得 108~109 年度及 110 年第一季不動產、廠房及設備週轉率與華邦電相當，尚無重大異常之情事。

D.總資產週轉率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之總資產週轉率分別為 0.81 次、0.51 次、0.60 次及 0.66 次。108 年度總資產週轉率皆較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願致營業收入減少，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 107 年增加；109 年度因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均總資產之幅度所致；110 年第一季總資產週轉率上升，係因半導體需求熱絡，該公司及其子公司產品銷售價格上升、銷售數量增加，營收成長成長所致。與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司總資產週轉率 107~109 年度及 110 年第一季皆介於採樣公司及同業平均，尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司之經營能力各項指標尚屬穩健，經評估尚無重大異常之情事。

2.獲利能力

評估項目		年度 公司	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至 3 月 31 日
獲利能力	權益報酬率(%)	力積電	23.37	(8.83)	12.07	25.10
		聯　電	1.26	2.96	12.27	16.30
		世　界	21.52	19.88	21.34	28.81
		華邦電	12.31	2.31	2.26	9.49
		同　業	1.70	1.60	註 2	
	營業利益占實收資本額比率(%)	力積電	247.77	(6.76)	18.50	36.59
		聯　電	4.67	3.99	17.72	24.54
		世　界	43.65	42.16	45.25	59.81
		華邦電	19.92	3.15	4.09	23.07
		同　業	註 1	註 1	註 1	
	稅前純益占實收資本額比率(%)	力積電	240.89	(8.42)	15.45	33.13
		聯　電	1.76	4.88	22.48	35.37
		世　界	45.59	44.90	46.17	61.34
		華邦電	21.09	4.40	4.55	22.05
		同　業	註 1	註 1	註 1	
	純益率(%)	力積電	13.85	(7.36)	8.33	15.92
		聯　電	1.75	4.14	15.37	21.00
		世　界	21.32	20.72	19.03	24.11
		華邦電	15.10	3.03	2.50	8.01
		同　業	8.10	6.40	註 2	
	每股稅後盈餘(元)	力積電	2.56	(0.94)	1.23	0.68
		聯　電	0.58	0.82	2.42	0.85
		世　界	3.76	3.58	3.85	1.35
		華邦電	1.87	0.32	0.33	0.40
		同　業	註 1	註 1	註 1	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比

率。

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率及每股稅後盈餘。

註 2：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版該年度之主要行業財務比率。

註 3：每股稅後盈餘係以基本每股盈餘作揭露。

(1)權益報酬率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之權益報酬率分別為 23.37%、(8.83)%、12.07%及 25.10%，108 年度股東權益報酬較 107 年度低且為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少且公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故權益報酬率由負轉正；110 年第一季權益報酬率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司權益報酬率 107 年度高於採樣公司及同業平均，108 年度華邦電及同業平均水準之權益報酬率亦較 107 年度下滑，惟該公司及其子公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司及其子公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司及其子公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；109 年度及 110 年第一季介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈權益報酬率逐漸上升，顯示該公司及其子公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

(2)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之營業利益占實收資本額比率分別為 247.77%、(6.76)%、18.50%及 36.59%；稅前純益占實收資本額比率分別為 240.89%、(8.42)%、15.45%及 33.13%，107 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率較高，係因該公司於 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組，收購力晶科技股份有限公司(以下簡稱力晶科)12 吋晶圓廠相關資產負債，並發行新股予力晶科作為取得對價，此交易係屬於共同控制下的組織重組，應追溯視為自始合併並重編比較期間之合併報告，於 107 年度業經重編後的營業淨利及稅前純益係涵蓋受讓業務，然 107 年度實收資本額則未改變仍為未併購前金額，致使該比率有較大差異；108 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術

平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率皆由負轉正；110 年第一季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較,該公司及其子公司營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率，107 年度高於採樣公司及同業平均，108 年度華邦電之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率亦較 107 年度下滑，惟該公司及其子公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司及其子公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司及其子公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；109 年度及 110 年第一季介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司及其子公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

(3)純益率及每股稅後盈餘

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之純益率分別為 13.85%、(7.36)%、8.33%及 15.92%；每股稅後盈餘分別為 2.56、(0.94)、1.23 及 0.68，108 年度純益率及每股稅後盈餘較 107 年度低且為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，致 108 年度處於虧損；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故純益率及每股稅後盈餘皆由負轉正；110 年第一季純益率及每股稅後盈餘增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司純益率及每股稅後盈餘，108 年度華邦電之純益率及每股稅後盈餘亦較 107 年度下滑，惟該公司及其子公司低於採樣公司及同業平均,主係因該公司及其子公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消

費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司及其子公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；107 年度、109 年度及 110 年第一季之純益率及每股稅後盈餘介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司及其子公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

3.本益比

請參閱本評估報告「壹、二、(一)、2、(2)、B 本益比法」之評估說明。

(三)所議定之承銷價格若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本次承銷價格之議訂並無採取專家意見或鑑價報告。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

該公司於 109 年 12 月 9 日於興櫃市場掛牌，最近一個月(110 年 6 月)之月平均股價及成交量分別為 64.78 元及 362,103 仟股。

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本證券承銷商經考量該公司之獲利能力、產業未來發展前景及初次上市股票流動性等因素，並參酌採樣同業公司之本益比以及該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價等方式，本證券承銷商與該公司共同議定之承銷價格暫定為每股 50 元。另實際承銷價格將於屆辦理上市前公開承銷時，採用詢價圈購或競價拍賣等方式發現市場合理價格，並於向券商公會申報詢圈或競拍約定書前，依券商公會再行銷售辦法之相關規定辦理，與該公司共同議定上市掛牌之承銷價格，期能訂定合理之承銷價格。

三、承銷風險因素

茲列示本次承銷相關風險因素如下：

(一)股價變化過鉅

該公司本次暫訂之承銷價格，已考量該公司未來經營績效、同業狀況及發行市場現況等因素後而予以調整，因此，本次承銷價格應尚能合理反映該公司之市場價值，且辦理公開承銷時，將針對市場對案件承銷價格的接受條件及認購情形進行調查，做為調整承銷價格之參考依據。另本證券承銷商亦已依「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」規定，擬定穩定價格策略，期能降低股價變化過鉅之風險。

(二)穩定價格策略

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本證券承銷商已與該公司簽訂「過額配售協議書」，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數之 15%為上限，提供已發行普通股股票供本

證券承銷商辦理過額配售。本證券承銷商負責規劃及執行穩定價格操作，以穩定承銷價格。

(三)本次承銷之相關費用及承銷手續費率

該公司本次辦理公開承銷所需之費用主要包括公開說明書印製費用、相關承銷書件印製費用、會計師與律師之勞務費以及承銷手續費等；而承銷手續費將參考未來辦理公開銷售時之市場行情議定，惟依國際財務報導準則實務指引(IFRS Manual of Accounting)及參酌 IAS32 第 37 段之說明，企業於發行或取得本身之權益工具時，通常會發生各種成本，此權益交易之交易成本應按扣除所有相關所得稅利益後之淨額作權益之減項處理，但以直接可歸屬該權益交易之可避免增額成本為限，而本次承銷手續費係可直接歸屬於該權益交易之可避免增額成本，故對該公司之獲利狀況並無重大影響。

(四)新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利

該公司本次預估辦理現金增資 2,000,000,000 元發行新股，與該公司擬掛牌之實收資本額 36,051,962,420 元相較，新股承銷導致股本膨脹對每股盈餘稀釋比率為 5.55%，惟本證券承銷商與該公司議定承銷價格時業已考量本次發行新股之稀釋效果，故對本次承銷風險之影響尚屬有限。

綜上分析，該公司已依法令規定計算應提出公開承銷股數，並全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，經評估本次新股承銷之相關費用對其獲利之稀釋程度有限，股本膨脹對該公司獲利之稀釋效果亦已於本次議定承銷價格時納入考量，另本證券承銷商已針對承銷價格擬定穩定價格策略，整體而言，其承銷風險應屬有限。

四、綜合具體結論

本證券承銷商經評估該公司及其子公司之財務及業務狀況後，綜合說明該公司及其子公司之營運風險及財務風險如下：

(一)同業競爭壓力增加

近年半導體產業主要支撐力道來自於行動裝置、5G、AI 等產品，各相關邏輯元件晶圓代工廠亦受惠，引起業界關注。而近年中國政府致力於半導體產業扶植，以打造產業鏈一條龍為目標，積極投入設備及廣納人才。在全球代工產能供給增加的情況下，可能會面臨與同業競爭壓力。

<u>因應對策</u>

該公司及其子公司 12 吋廠自 101 年起成功轉進晶圓代工業務，以世界級同步的技術，搭配國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的代工服務，以共創事業高峰。至今已陸續引進不同的代工客戶，客戶的產品可應用的範圍涵蓋了 3C 應用領域－電腦、無線通訊、消費性電子及車用電子等。

同時藉由擴大與全球產官學研究機構共同進行相關製程技術開發，以期提早掌握前瞻技術，有效縮短研發時程，降低專利與技術移轉成本。該公司及其子公司持續提供更優質的服務、產品及多元代工模式，以持續深化與客戶良好關係，為該公司及其子公司最佳的因應之道。該公司及其子公司的 12 吋廠與 8 吋廠整合後，將可提供客戶更完整的產品線及更完善的服務品質。

(二)產能擴充之可能風險

因 12 吋代工客戶產能需求持續攀升，該公司及其子公司 12 吋產能已常態性無法滿足客戶需求。為滿足中長期營運規劃，該公司及其子公司在充分評估後，已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構該公司及其子公司最新 10 萬片 12 吋生產基地。惟因需求預測會隨著市場環境變化而產生顯著的改變，當需求減少時，已添購的機器設備及增聘的人員等將造成對該公司及其子公司財務表現產生負面的影響。

因應對策

該公司及其子公司會持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，若市場需求不如預期時，該公司及其子公司會及時地調整其產能計劃，以降低對於公司財務表現的負面影響，且該公司及其子公司相關投資計畫尚在規劃中，原則以分期、分階段，以公司財務可負擔，最小風險下擴充廠房及產能，同時兼顧公司穩健成長與滿足客戶產能需求。

該公司及其子公司亦將擴廠設備風險轉嫁給客戶共同承擔，對上游 IC 設計業者來說，即使本身公司設計具有競爭力，但沒有配合製造的產能也無濟於事，因此未來五年，邏輯晶圓代工產能將成為兵家必爭之地，而客戶端爭搶產能動作更加積極。目前該公司及其子公司與部分客戶間採取託管(Consign)的模式，由客戶購買機器設備租予該公司及其子公司，再由該公司及其子公司代工產出產品，客戶可確保後續晶圓取得無虞，該公司及其子公司也能降低購買大量設備後需求減緩的風險。

(三)有關智慧財產權之風險

該公司及其子公司係以自行研發的製程技術、營業秘密、相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，然而尚無法保證營業秘密及相關 know-how 不被竊取或仿效，若發生此情事，將導致該公司及其子公司營收減少之可能性，也有可能在不知情的情況下侵害到他公司的智慧財產權，若有相關訴訟可能導致該公司及其子公司有無法製造特定產品的風險。

因應對策

該公司及其子公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益損失的可能性。包含積極主張及保護該公司及其子公司所屬之智慧財產權，對於研發成功之產品基於智慧財產權，皆有申請專利保護。該公司及其子公司設有智權室防止製程中有侵害他人智慧財產權之情事，另外對於使用到的專利，皆有取得其他公司的授權，避免有侵權的風險。

(四)綜合結論

綜上所述，本證券承銷商針對該公司及其子公司所處行業之營運風險、該公司及其子公司之經營體質及其營運和財務風險綜合評估，該公司及其子公司已具備降低或分散風險之能力，且其經營穩健、獲利情況穩定，企業體質良好，本證券承銷商並就該公司申請上市各項基本條件進行檢視及不宜上市條款之查核，據此評估該公司以符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」所規定之上市標準，且其產業未來前景應屬樂觀，該公司若能經由上市之路，透過資本市場募集長期發展所需之資金，並藉此提高公司知名度及吸引優秀人才，對該公司永續經營及社會廣大投資人均有所助益，故本證券承銷商推薦該公司申請股票上市。

貳、產業狀況及營運風險

一、發行公司所屬行業之營運風險

(一)產業概況

該公司及其子公司主係從事半導體晶圓代工服務，主要產品分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，為各種電子產品中不可或缺的關鍵原料。邏輯暨特殊應用產品晶圓代工產品包含高壓製程產品、分離式元件產品、CMOS 影像感測器產品、電源管理晶片產品及嵌入式非揮發記憶體產品等；記憶體產品晶圓代工產品包含動態隨機存取記憶體產品及快閃記憶體產品(NAND/NOR Flash)。該公司及其子公司所生產之產品主係應用於電腦產品(Computer)、通訊應用(Communication)、消費性電子(Consumer)及車用電子(Automotive)等電子終端產品，茲就該公司及其子公司產品概況說明為：

1.全球半導體產業概況

半導體技術的發展可追溯到一百年以前，從 1960 年代開始將電晶體、電阻及電容放在一個小矽晶片上構成大而複雜的電路，甚至整個系統(如計算機、收音機、電視機)，堪稱半導體積體電路(Integrated circuit：IC)之先驅，並帶動了科技呈現跳躍式的發展。IC 晶片為所有設備或裝置的基礎，藉由編輯應用程式控制設備或裝置，不斷改變人類的生活。複雜的半導體晶片可以協助智慧型手機、汽車、使用網路、雲端數據、工業自動化、智能家庭和消費性電子產品的技術發展，反過來說，隨著對關鍵技術發展要求及需求的成長，對半導體的需求也呈現成長趨勢。

主要科技應用程式潛在市場(單位:10 億美元)

資料來源：星展銀行整理

在 108~109 年各國開始全力支援 5G 商轉，領先推出的國家有南韓、美國、澳洲、英國及中國大陸等國，宣告全球正式邁入 5G 世代，110 年將有更多品牌廠商推出多款 5G 手機。5G 技術以高速傳輸、低延遲及大量連網為特色，除了 5G 基礎建設帶動的商機，也將引發終端設備新一波的升級換機需求。

另隨著運算能力增加及資料傳輸速度的提昇、各種網路及雲端數據蒐集技術逐步成熟的情況下，利用數據發展人工智慧(Artificial Intelligence，AI)成為近年相當

重要的科技議題，預估 AI 在終端裝置上的應用，將朝向以下六大方向進行：語音助理、進階攝影、直覺化使用介面、降低功耗以延長電池使用時間、增進連線品質與增加個人安全性防護等。AI 也逐步往全方位的終端應用發展，包括智慧型手機、智慧穿戴、無人機、智慧家居、智慧工廠、智慧駕駛輔助，智慧行動醫療、公共／安防管理或是基因序列等終端應用都將接軌 AI。待 5G 商轉有成及 AI 時代來臨，串連起物聯網、車聯網、智能環境、人像或語音辨識等應用場景及行為習慣，將帶來半導體產業一連串的變化與商機。

同時因 AI 技術及效能的提升，物聯網及 5G 行動通訊建設臻於完善，興起許多新型態終端產品，使晶片設計複雜度不斷提昇；除追求晶片功能整合及低功耗外，還需考慮生產效能或是進一步要求半導體製程技術微縮。12 吋晶圓廠已經是半導體的主流供應尺寸，產業新競爭者的進入門檻較過去要更高。加上近幾年，全球 IDM 大廠朝向 Fab-lite 轉型趨勢漸趨明顯，逐步擴大晶圓委外代工訂單，臺灣晶圓代工產業成為這波轉型潮最大受惠者。該公司及其子公司擁有充裕的 12 吋先進製程晶圓產能並專注於利基型的製程，已陸續吸引許多國際 IDM 廠及無晶圓(Fabless)設計公司成為該公司及其子公司的代工客戶。

有鑑於 AI 及 5G 產業的逐漸成熟，未來終端產品對於高速及低功耗的客製化產品需求更甚，該公司及其子公司針對此市場趨勢，積極開發更符合客戶需求的特殊邏輯製程及記憶體產品製程，以提供客戶更具市場競爭力的晶圓代工服務。

回顧 109 年，年初因受新冠肺炎疫情肆虐及多國實施封城措施，使各國經濟成長受到影響，失業率攀升，但全球半導體產業卻因新冠肺炎疫情而受惠。新冠肺炎疫情迫使人們行為從「實體轉向虛擬」而帶動宅經濟，各類「宅經濟」相關晶片需求相對穩健，如電視機上盒(STB)晶片、遊戲用 PC、家用遊戲機熱銷、支援遠距教學及遠端辦公的伺服器晶片、安防監控相關晶片等。隨著各式電子產品需求逐漸回溫，又因恐新冠肺炎疫情再次升溫而斷料的恐慌心理，使各供應鏈提前備料更加積極，導致上游晶圓代工廠產能吃緊，產能供不應求。展望 110 年，5G、AI、遠距需求及電動車仍為帶動產業成長的主要動能，將帶動晶圓代工、IC 設計、Wi-Fi 6、矽晶圓、設備材料、車用電子、動態隨機存取記憶體(DRAM)、被動元件、5G 設備等需求旺。110 年半導體產業將延續 109 年的供需吃緊狀況。

2.晶圓代工產業概況

(1)晶圓代工產業整體概況

半導體之製程技術及產品良率與生產成本關係密切，故各廠商為達到規模經濟之生產，莫不致力於產品良率與製程技術之提昇。根據摩爾定律，每隔兩年晶片內之電晶體數目就會成長一倍，在近幾年製程進步速度加快下，其兩年之時間已縮短到一年半，因此本產業不但具有高度之技術水準，且技術變化速度亦相當快。

全球晶圓代工的模式興起於 1980 年代，由台灣積體電路製造股份有限公司開啟了專業晶圓代工之時代。邏輯晶圓主要用於智慧型手機、高效能運算、物聯

網、車用電子與消費性電子產品。

若以晶圓尺寸來區分，主要分為 8 吋及 12 吋，一般認為 12 吋晶圓優於 8 吋晶圓，係因更大的晶圓尺寸可以減少浪費，而且還可以提高晶圓代工廠的日產量。然而，8 吋晶圓的生產線非常成熟，部分晶圓代工廠設備已攤提完折舊，價格較具競爭優勢，生產主力為功率元件、電源管理 IC、影像感測器、指紋辨識晶片和顯示驅動 IC 等產品。根據 IC Insights 研究，在 5G 智慧型手機對應用處理器需求增加的推動下，純晶圓代工廠預計在 2020 年占晶圓代工廠總銷售額的 84.1%，從 2019 年到 2024 年，純晶圓代工廠的銷售預計達到複合年增長率 9.8%。

資料來源：IC Insights，SemiMedia(2020/09)整理

(2)晶圓代工製程技術

107 年 8 月底全球第二大晶圓代工廠 GlobalFoundries Inc.(GF)宣布退出 7 奈米及以下先進製程的研發與投資，這是繼聯華電子股份有限公司後第二家宣布放棄 10 奈米以下製程的半導體公司。摩爾定律在 28 奈米節點之後，提升幅度減緩顯示先進邏輯製程不是市場唯一方向，放棄燒錢無止境的先進製程，轉向更有利潤的特殊應用產品市場，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊應用製程(應用於顯示驅動 IC、電源管理晶片、分離式元件、CMOS 影像感測器、嵌入式非揮發記憶體之製造)及多元代工合作模式，以有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是該公司及其子公司的競爭策略，28 奈米以上成熟製程市場依然有相當大的規模，包括 IoT、工業、汽車電子等應用。

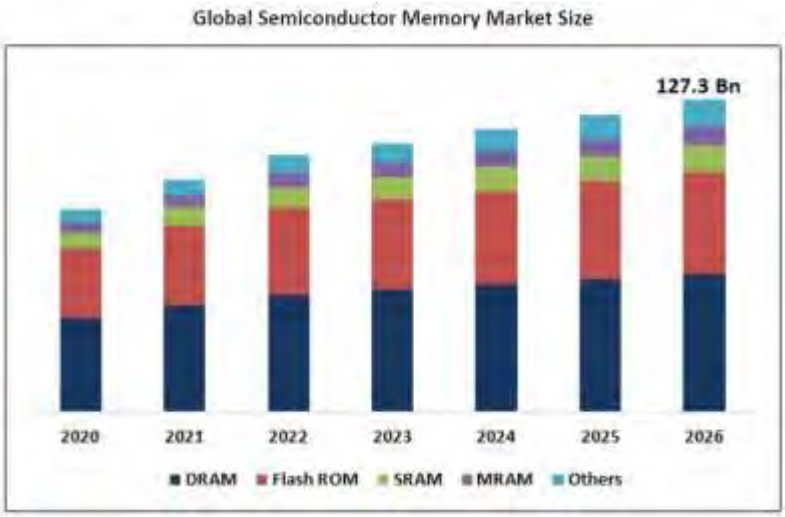
製程演變

資料來源：工業技術研究院(2020/10)

3.記憶體產業概況

(1)記憶體產業整體概況

記憶體晶圓之製成品，依產品別可分為「記憶體模組」(DRAM Module)及「快閃記憶卡」(Memory Card)兩大類，前者主要應用於筆記型電腦(Notebook, NB)、桌上型電腦(DT)、伺服器(Server)及工業電腦(Industrial Personal Computer, IPC)等產品，後者則多應用於如數位相機、智慧型手機、電子遊戲機、平板電腦及攝/錄影機等可攜式電子產品。



資料來源：KBV Research(2020/07)

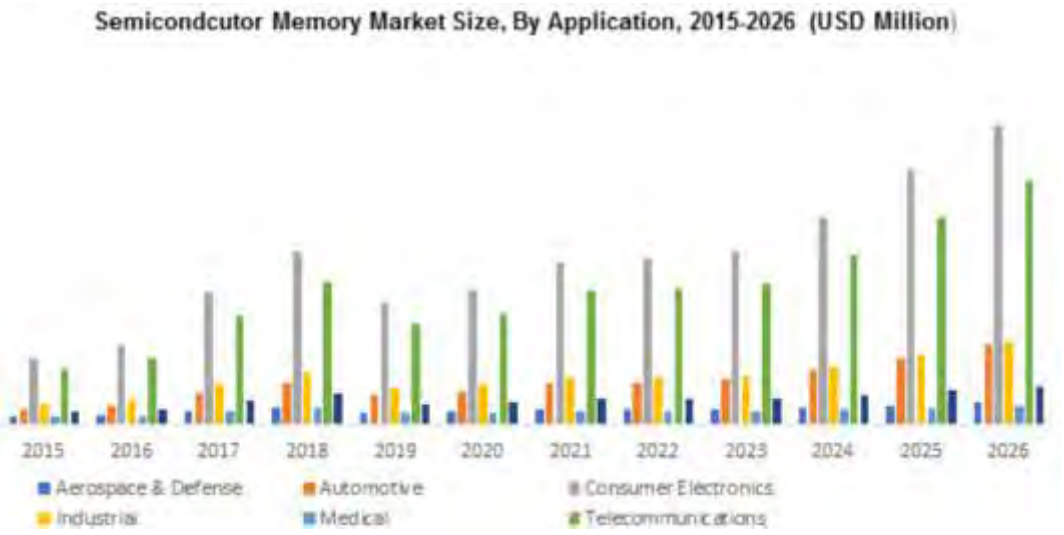
近年來，由於各大智慧型手機品牌商開始提高旗下手機 DRAM 的搭載率，以及美國、中國等主要國家加快大型資料中心的建置進程，而且為因應人工智慧(AI)、大數據(Big Data)、邊緣運算(Edge Computing)及伺服器(Server)等進階運用，因而對於 DRAM 及 NAND 型快閃記憶體(NAND Flash)有較顯著之需求。

107 年開始受到美中貿易戰、智慧型手機、伺服器等主要消費終端市場需求較為疲弱等因素影響，使得 DRAM 和 NAND Flash 價格皆出現大幅走跌，其中在 NAND Flash 方面，製程良率提高所造成的供給持續增加，加上買家縮手但供應商卻有較多庫存想賣，皆促使 NAND Flash 市場在 108 年第一季以前處於更明

顯之供給過剩狀態，使得下游應用產品外銷力道明顯減弱。然而，自 108 年第二季以來，NAND Flash 現貨價受惠於庫存去化已至尾聲、日韓貿易爭端刺激下游廠商提前備貨，以及東芝跳電停產減少供給而開始反彈，另外 DRAM 價格亦於 108 年 6 月出現落底跡象。

109 年開始，由於新冠肺炎疫情所衍生之電子競技、遠距工作及線上教學需求有效帶動伺服器及 NB 等相關記憶體的銷售，居家辦公及網路授課者對於消費型快閃記憶卡也具較顯著之需求。

記憶體晶圓未來成長動能為 5G 手機記憶體容量增加、高效能運算(Server/HPC)需求持續成長及車用/IoT 產品運算效能提升需求。根據 Global Market Insights 研究，記憶體半導體應用以消費性電子產品為大宗，其次是通訊產品。



資料來源：Global Market Insights(2020/02)

(2)動態隨機存取記憶體製程技術

由於終端電子產品需求朝向性能提升、輕薄化及節能等趨勢下，晶片設計更需高度功能整合，其在高效能與低功耗等需求更需較高階製程記憶體產品支持。目前利基型動態隨機存取記憶體代工已導入 25 奈米製程，同時更加速 25 奈米以下新製程平台開發。另有因應人工智慧之類神經網路計算系統所需 AI Memory(記憶體式運算, In-Memory Computing；IMC)，並開發能與邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體，以滿足客戶不同的客製化記憶體需求，這些都能突顯該公司及其子公司提供記憶體產品代工之產業的地位。該公司及其子公司正與客戶或其他主要供應商密切合作，以切入成長強勁的人工智慧領域需求的半導體市場。

(3)快閃記憶體(NAND/NOR Flash)製程技術

該公司及其子公司瞄準行動應用裝置、消費性電子產品及工業應用市場，提供低功率節能及高可靠度的 Flash 產品。低容量 NAND Flash 搭配 low-power DRAM 成為入門無線通訊產品主要的記憶體方案。此外，低容量 NAND Flash 也

普遍運用於消費性電子產品、通訊產品及汽車聯網或工業應用。目前 28 奈米 NAND Flash 製程已成功進入量產階段。

近年來，許多新興的應用創造更多的 NOR Flash 記憶體需求，如無線藍牙耳機(TWS)、有源矩陣有機發光二極體面板(AMOLED 面板)或是 5G 基站設施都有 NOR Flash 需求。因應這些新興應用產品需求，帶動全球 NOR Flash 市場觸底反彈，回到全球年營業額 20 億美金以上。該公司及其子公司積極開發新一代 48 奈米 NOR Flash 製程，已於 110 年第二季量產；將能提供客戶更高容量、更有成本競爭力並能兼顧品質可靠度要求的 Flash 產品。

(二)行業營運風險

1.景氣循環之營運風險

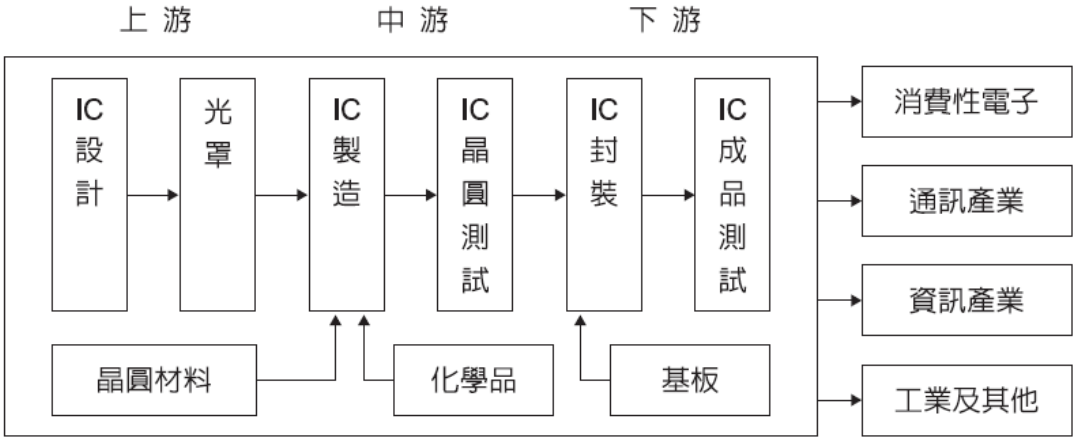
該公司及其子公司憑藉研發團隊多年研發設計經驗，以及與客戶多年合作關係，能夠快速提供符合客戶需求之客製化產品，各製程需要昂貴的設備、專利及良率關鍵 Know-how，進入門檻較高，產品應用面廣泛，因此該產業較無產品生命週期短促或產品世代交替快速之風險。

該公司及其子公司目前以生產記憶體晶圓、邏輯晶圓為主，生產排程配合市場價格及終端市場需求轉換產能，當單一終端產業受到季節性因素衝擊時，因記憶體晶圓、邏輯晶圓應用層面廣泛因而可分散風險，較不易受到景氣循環之波動而產生顯著負面影響。

在新冠肺炎疫情之下，各國紛紛實施封城計畫、居家辦公及遠距教學之下，帶動資料中心、筆電、平板電腦、固態硬碟及網通設備等產品的出貨量，同步刺激相關晶圓代工。又由於人們不敢搭乘大眾交通工具，在防疫規範逐步放寬後，汽車的需求量直線攀升，進而引發車用晶片短缺危機。近年來 5G、人工智慧物聯網(AIoT)等快速興起，也需要大量的晶圓。綜上所述，顯現目前半導體產能不足，該行業尚處於成長之利基市場，並無明顯景氣循環之營運風險。

2.行業上中下游變化之營運風險

半導體產業，泛指所有 IC 設計、生產製造及封裝測試半導體元件相關產品的產業。依功能可將積體電路分為四類產品：記憶體 IC、微元件、邏輯 IC 及類比 IC。IC 設計的種類很多，且具有不同特性，對於製程上的要求也不同，故晶圓製造廠及產業鏈間也須與客戶設計及製程需求與時俱進，以符合終端產品規格，並帶動整體產業鏈發展；故半導體產業之上、中、下游之關聯性為：



資料來源：工研院經貿中心 ITIS 計畫、該公司及其子公司提供，元大證券整理

3.行業未來發展

(1)高效能、高頻寬、低功耗

隨各項電子終端產品，如電腦產品(Computer)、通訊應用(Communication)、消費性電子(Consumer)及車用電子(Automotive)產品等生產技術漸趨成熟，智慧型手機產品的普遍級人工智慧相關產品的推出，促使物聯網(IoT)產業鏈逐漸成形，更帶動上下游相關元件需求。終端產品要求「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，對晶圓代工廠而言，提供客戶客製化製程開發晶圓之體積小、低耗電量及多功能更顯重要，邏輯晶圓與 DRAM 晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的 AI 晶片，兼具高效能、高頻寬及低功耗優勢的新世代半導體製造技術突破，預料將為晶圓代工產業開創新局。

(2)新應用市場需求旺盛

車用、5G 及人工智慧物聯網(AIoT)等晶片快速興起，已對全球半導體產業造成結構性的改變，目前市場對成熟製程的晶片需求出現大爆發的情況，未來供不應求將更嚴重。許多國家近期皆洽詢其他國家半導體製造商，希望取得晶圓產品的供應，以德國為例，經濟部長洽詢臺灣半導體製造業者，渴望半導體製造商製造排程順序能夠調整，以為該國車用廠商優先取得車用晶圓，緩解其製程瓶頸。新的智能終端產品層出不窮，使晶圓市場前景越來越廣闊，未來晶圓供不應求的趨勢將會更加顯著。

(3)中國政府強力扶植中國半導體製造業

中國政府祭出多項扶植政策來強化半導體鏈國產化的發展速度，如積極採取政策、資本、創新等三方的扶植政策，例如：(一)二期積體電路大基金：除了布局投資製造類、擴大對設備及材料領域的投資，亦會布局 5G、AI 相關設計領域，顯然投資範圍較一期積體電路大基金為大。(二)新時期促進積體電路產業與軟體產業高品質發展若干政策：主要以稅賦的減免為主。(三)將第三代半導體列入十四五計畫、中共中央關於制訂國民經濟及社會發展第十四五年規劃和 2035 年願

景目標的建設：尚未對實際的作法有更深入的方針。

(4)美國奪回半導體產業主導權

在新冠肺炎疫情及美中貿易戰之下，為鞏固美國在未來新興科技領域的全球領導地位，美國體認到自主控制供應鏈的重要性，因而實施：(一)加強投資美國國內半導體產業：美國半導體產業協會(SIA)建議美國政府投入 370 億美元籌組美國國家隊。(二)拉攏外國半導體製造業至美國設廠：台積電於 2020 年 5 月 15 日宣布將在美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，將採用 5 奈米製程，預計 2021 年動工、2024 年量產，投資金額約 120 億美元。(三)切斷華為供應鏈，影響相關半導體產業：美國修改出口管理條例，要求全球所有公司只要利用到美國的設備和技術幫華為生產產品，都必須經過美國政府批准，另一方面，中國方面也開始反擊，對重量級美國企業展開報復(施以反壟斷或網路安全調查)，要求中國科技供應鏈加速去美國化。

4.產品可替代性之營運風險

晶圓運用之範圍相當廣泛，各項電子終端產品，如電腦產品、通訊應用、消費性電子、車用電子產品及物聯網(IoT)相關產品等皆必須使用晶圓，因此下游終端產業的成長，將帶動對晶圓的需求成長。在 5G 及高效能運算(HPC)需求帶動下，市場出現結構性變化，加上全球經濟改變，現代人們工作及生活型態都不同以往，推升晶圓成為不可或缺的產品，尚無其他產品可替代。

二、發行公司營運風險

(一)業務之營運風險

1.市場未來供需變化情形

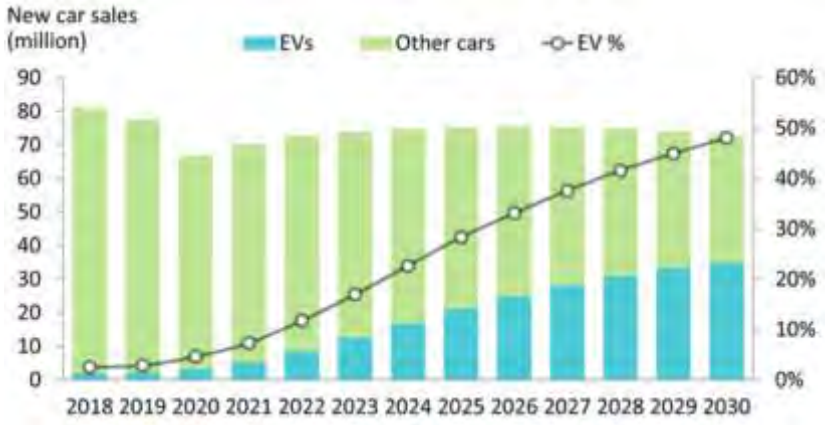
根據 WSTS(全球半導體貿易統計協會)統計 109 年全球半導體，市場產值達 4,330 億美元，較 108 年的 4,123 億美元增長 5.1%，較先因前受新型冠狀病毒(COVID-19)影響下修至 3.3%的成長預期為優。WSTS 預計 110 年全球半導體市場增長將加速，110 年全球半導體產值可望年增約 8.4%，主要成長動能來自於 Sensor、Logic 及 Memory 等相關產品；研調機構顧能 Gartner 也預期 110 年半導體市場將成長 11.6%以上水準。近年由於 IDM 大廠在樽節資本支出及降低成本考量下，增加委外代工比重，有助於晶圓代工廠營收表現。根據國際研究機構 Omdia 預估 110 年純晶圓代工產值預期有 15.4%的正成長，表現相對優於整體半導體產業。

自新冠肺炎疫情爆發以來，迄今已擴散全球，目前尚未能有效控制，加上中美貿易戰日益加劇，引發市場多種不確定性，或對於產品終端需求造成遞延效應，需更密切觀察其後續對全球經濟造成的影響。

車用(電動車、Smart Car 自動駕駛)、5G、AloT (小型處理器)等晶片新需求快速興起，已造成全球半導體產業結構性的改變，目前市場對成熟製程的品片需求出現大爆發，而且未來供不應求將更嚴重。

汽車工業已經從單純機械組裝製造發展到安裝電子零組件藉以提升性能、效率、安全性和舒適性。目前的汽車創新主要是電子功能創新，並逐步往自動駕駛邁進。109 年電動汽車占所有新車銷售約 5%，預計 110 年電動汽車將占全球新車銷售的 7%以上，銷量將超過 500 萬輛；預計到 119 年，電動汽車將占全球乘用車總銷量的近一半。

2018 年~2030 年汽車變化情形



資料來源：Canalys estimates(2021/01)

隨著智能手機從 4G 往 5G 邁進，雖 5G 網絡基礎建設的進度尚未普及，但各家智慧型手機品牌和移動處理器製造商為搶得商機，皆努力擴大在 5G 市場的份額，根據 TrendForce 研究報告，109 年 5G 智慧型手機已達 18.9%，110 年將成長至 39.5%，預計 111 年將達智慧型手機半數。

資料來源：TrendForce(2020/07)

2.該公司及其子公司之地位及市場占有率

該公司及其子公司主係從事半導體晶圓代工服務，主要產品分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，根據國際研究機構 Omdia 針對 109 年全球晶圓代工總產值預估達 664 億美元；統計該公司及其子公司 109 年全年合併營收為新臺幣 465.8 億元，在全球晶圓代工市占率約達 2.3%，排名第六大。然該公司及其子公司在資源整合效益下，未來市占率可望有所提升。

3.影響該公司及其子公司未來發展之有利及不利因素及其相關因應措施

(1)有利因素

A.市場需求穩定成長

物聯網及人工智慧的發展，創造許多由 Cloud 端到 Edge 端不同且多樣的半導體需求。在全球智慧手機發展成熟之際，提供了另外一項半導體市場長期的成長動能。於邏輯產品之技術方面，該公司及其子公司充份發揮 12 吋 80nm 以上鋁製程成本優勢，在 DDIC/PWM/MCU/CIS 等特殊代工產品領域與客戶深度合作，並進一步延伸至 55nm 以下銅製程。於 8 吋則重心由 IC 擴大至分立器件，以 MOSFET/IGBT/GaN 等產品線為未來主要成長動能。8 吋及 12 吋未來目標是都要能兼顧穩定獲利及持續成長。另，於記憶體產品之技術方面，該公司及其子公司除擁有完整的記憶體設計服務及製造能力外，且同時具備 DRAM 及 NAND/NOR Flash 製程平台，能夠滿足客戶多元化的記憶體產品需求。該公司及其子公司將持續開發新一代記憶體製程，維持成本競爭優勢，並與代工客戶共同合作提供多樣化、高品質的記憶體產品。

B.產品多元

該公司及其子公司兼容邏輯製程及記憶體製程代工產能配置，有利於公司於景氣波動循環中進行產能彈性調配，提高產能利用率，使該公司及其子公司能維持相對於代工同業較佳的穩定獲利。

C.高客製化程度

該公司及其子公司以先進技術提供 8 吋及 12 吋晶圓專業代工服務。不僅提供利基型記憶體先進製程以協助國內外客戶生產相關產品，為目前全球主要提供全方位記憶體產品線代工之 12 吋晶圓廠。同時，提供客製化的邏輯暨特殊應用產品代工服務，成為世界級大廠的最佳合作夥伴。

(2)不利因素

A.同業競爭壓力增加

近年半導體產業主要支撐力道來自於行動裝置、5G、AI 等產品，各相關邏輯元件晶圓代工廠亦受惠，引起業界關注。而近年中國政府致力於半導體產業扶植，以打造產業鏈一條龍為目標，積極投入設備及廣納人才。在全球代工產能供給增加的情況下，可能會面臨與同業競爭壓力。

<u>因應對策</u>

該公司及其子公司以世界級同步的技術，搭配國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的代工服務，以共創事業高峰。至今已陸續引進不同的代工客戶，客戶的產品可應用的範圍涵蓋了 3C 應用領域－電腦、無線通訊、消費性電子及車用電子等。

同時藉由擴大與全球產官學研究機構共同進行相關製程技術開發，以期提早掌握前瞻技術，有效縮短研發時程，降低專利與技術移轉成本。該公司及其子公司持續提供更優質的服務、產品及多元代工模式，以持續深化與客戶良好關係，為該公司及其子公司最佳的因應之道。該公司及其子公司的 12 吋廠與 8 吋廠整合後，係可提供客戶更完整的產品線及更完善的服務品質。

B.產能擴充之可能風險

因 12 吋代工客戶產能需求持續攀升，該公司及其子公司 12 吋產能已常態性無法滿足客戶需求。為滿足中長期營運規劃，該公司及其子公司在充分評估後，已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構該公司及其子公司最新 10 萬片 12 吋生產基地。惟因需求預測會隨著市場環境變化而產生顯著的改變，當需求減少時，已添購的機器設備及增聘的人員等將造成對該公司及其子公司財務表現產生負面的影響。

因應對策

該公司及其子公司會持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，若市場需求不如預期時，該公司及其子公司會及時調整其產能計劃，以降低對於公司財務表現的負面影響，且該公司及其子公司相關投資計畫尚在規劃中，原則以分期、分階段，以公司財務可負擔，最小風險下擴充廠房及產能，同時兼顧公司穩健成長與滿足客戶產能需求。

該公司及其子公司亦將擴廠設備風險轉嫁給客戶共同承擔，對上游 IC 設計業者來說，即使本身公司設計具有競爭力，但沒有配合製造的產能也無濟於事，因此未來五年，邏輯晶圓代工產能將成為兵家必爭之地，而客戶端爭搶產能動作更加積極。目前該公司及其子公司與部分客戶間採取 Consign 的模式，由客戶購買機器設備租予該公司及其子公司，再由該公司及其子公司代工產出產品，客戶可確保後續晶圓取得無虞，該公司及其子公司也能降低購買大量設備後需求減緩的風險。

C.有關智慧財產權之風險

該公司及其子公司係以自行研發的製程技術、營業秘密及相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，然而尚無法保證營業秘密及相關 know-how 不被竊取或仿效，若發生此情事，將導致該公司及其子公司營收減少之可能性，也有可能在不知情的情況下侵害到他公司的智慧財產權，若有相關訴訟可能導致該公司及其子公司有無法製造特定產品的風險。

因應對策

該公司及其子公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益損失的可能性。包含積極主張及保護該公司及其子公司所屬之智慧財產權，對於研發成功之產品基於智慧財產權，皆有申請專利保護。該公司及其子公司設有智權室防止製程中有侵害他人智慧財產權之情事，另外對於使用到的專利，皆有取得其他公司的授權，避免有侵權的風險。

D.氣候災害風險

半導體製造業對電力的供電量及穩定度皆有強大的要求，若發生偶發性斷電將需要重啟設備及檢查機台，因而影響產品製程進度。半導體製造業對營業用水需求量大，若有缺水的情況也將影響產能。任何氣候災害造成缺水缺電皆有影響產能的風險。

因應對策

該公司及其子公司設有不斷電系統，避免有斷電的情況，對於水資源致力回收使用，減少對水資源的損耗，並對無法於廠內再次使用之廢溶劑落實機台分流設計，於排放管路裝上選別閥進行切換排放管路，有效減少廢溶劑之排放量，且將其餘廢水排入廢水場或回收系統，進行水回收使用，使得該公司及其子公司 109 年度 8A 廠製程用水回收率達 85%以上。

該公司及其子公司與政府部門有良好的溝通渠道，氣候災害風險管控皆有充分討論因應對策，並已密切監控水情狀況，於水源吃緊時備妥水車，一旦有需要便可啟動至與政府協商的地區載水應急。

E.匯率風險

該公司及其子公司營收不論內外銷，皆採外幣計價，交易幣別採美元交易，惟該公司及其子公司資本支出及進貨付款幣別主要有美元、日幣及新臺幣，無法互抵之美元應收款項在轉換成新臺幣時，仍會因持有美元淨資產部位而產生匯兌損益。故在美元持續貶值趨勢之情況下，兌換損失可能將侵蝕公司之獲利。

因應對策

該公司及其子公司因應匯率變動之管理以避險為目的，不以獲利為目的，採自然避險及配合遠期外匯合約以規避匯率風險;另財務單位密切留意國際金融狀況，掌握最新之匯率市場變動，並請往來銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率走勢，並視實際外幣部位和資金狀況，於政策許可之範圍內，配合遠期外匯合約以規避匯率風險。

4.公司競爭利基

(1)專業研發團隊

研發人才與製程技術具有密切的關係，若僅具有先進之設備與製程參數，無優秀之研發人才則不易發揮良好的生產效率。該公司及其子公司深知優秀人才為公司永續經營之重要因素，故藉由配股及分紅制度吸引優秀研發人才，該公司及其子公司之研發團隊碩博士以上學歷員工占研發人員比率半數以上，最近期為68.22%，且大多已具備相關產業研發工作資歷。

該公司及其子公司之技術研發主係專研各種邏輯與記憶體代工製程技術平台，為客戶提供一流之代工服務，以期在邏輯代工與記憶體代工製程技術上與世

界一流廠商並駕齊驅。截至目前為止，該公司及子公司已取得 943 項專利權且尚有 335 項申請中專利權。

(2)價格競爭優勢

該公司及其子公司 8 吋及 12 吋廠製程良率優異，與世界大廠同步，在先進製程上具備成本競爭力優勢，並與策略聯盟夥伴合作建立共同的設計平台和 IP，提供客製化的晶圓代工服務，包括邏輯暨特殊應用產品、利基型動態隨機存取記憶體及 NOR/NAND 快閃記憶體等領域的晶片專業代工服務，並積極導入國際大廠與之合作，開發多樣產品。以世界級同步的製造技術及國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的優異代工服務。

而有別於一般市面上 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，該公司及其子公司能提供低成本的 12 吋鋁製程平台，相較同樣技術節點的 8 吋鋁製程，該公司及其子公司 12 吋鋁製程晶粒成本可大幅降低 30%以上，大幅提昇客戶產品競爭力。

(3)邏輯晶圓與 DRAM 晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的 AI 晶片

考量到終端電子產品需求朝向性能提升、輕薄化及節能等趨勢下，晶片設計更需高度功能整合，其在高效能與低功耗等需求更需較高階製程記憶體產品支持。目前利基型動態隨機存取記憶體代工已導入 25 奈米製程，同時更加速 25 奈米以下新製程平台開發。另有因應人工智慧之類神經網路計算系統所需 AI Memory(記憶體式運算, In-Memory Computing；IMC)，並開發能與邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體，以滿足客戶不同的客製化記憶體需求，這些都能突顯該公司及其子公司提供記憶體產品代工之產業的地位。該公司及其子公司正與客戶或其他主要供應商密切合作，以切入成長強勁的人工智慧領域需求的半導體市場。

(二)技術能力、研發及專利權之營運風險

1.取得技術專家之評估意見佐證

本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就該公司及其子公司之研發技術能力出具意見或報告，故不適用本評估事項。

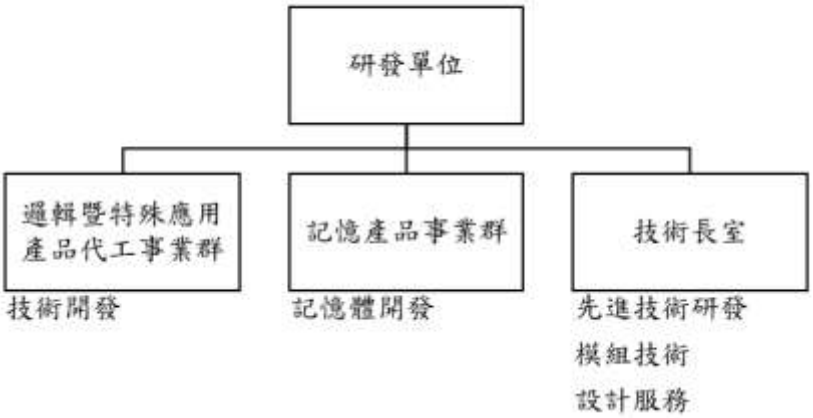
2.取得發行公司研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以了解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近期及最近三個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對發行公司之營運風險

(1)研發部門之沿革及組織

該公司及其子公司為厚植技術競爭力，成立研發團隊，研發組織架構係採專業分工管理，研發主管其下轄單位為技術開發、記憶體開發、先進技術研發、模組技術及設計服務。茲將該公司及其子公司研發部組織圖及所轄各職掌分別列示

如下：

A.研發部門組織圖



資料來源：該公司及其子公司提供

B.研發單位職掌

單位	工作內容
技術開發	開發邏輯及特殊運用產品之製程技術，以增加晶圓代工產能利用率，並將已開發之新製程移轉至 FAB 廠順利量產，累積技術開發能力。
記憶體開發	DRAM 與 FLASH 技術研發之規劃、評定、驗證及自有、代工產品之量產。
先進技術研發	執行平台技術、應用技術及特殊邏輯技術之開發計畫，並順利導入量產。
模組技術	模組製程技術開發與導入並負責量產前之維護，持續導入新製程及材料以符合客戶產品世代的演進。
設計服務	建立自有IP開發與分析的能力，並建立維護及管理，驗收內容與驗證機制。

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)最近期及最近三個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、學經歷、流動情形及離職率

單位：人；年；%

年度		107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至 6 月底
期初人數		742	1,129	1,107	1,162
新進人員		87	53	124	57
離職人員		69	60	70	37
資遣人員		—	6	3	1
退休人員		—	2	1	0
部門異動		369	(7)	5	(4)
期末研發人員合計		1,129	1,107	1,162	1,177
平均年資(年)		8.02	8.68	8.96	9.20
離職率(註)		5.76%	5.79%	5.99%	3.13%
學歷分佈	博士	33	37	42	45
	碩士	693	685	743	758
	大學(專)	384	366	357	353
	高中(職)及以下	19	19	20	21

資料來源：該公司及其子公司提供

註：離職率=(離職人數+資遣及退休人員)／(期末人數+離職人數+資遣及退休人員)。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至 6 月底研發人員分別為 1,129 人、1,107 人、1,162 人及 1,177 人，最近三年及最近期研發人員占公司員工總數分別為 16.29% 、16.09%、16.20%及 16.28%，顯示該公司及其子公司對研發相當重視，其中博士以上學歷員工分別為 33 人、37 人、42 人及 45 人，碩士以上學歷員工分別為 693 人、685 人、743 人及 758 人，碩博士占研發人員比率分別為 64.30%、65.22%、67.56%及 68.22%，占總研發人員半數以上，且大多已具備相關產業研發工作資歷，顯示該公司及其子公司對研發人員之素質相當重視。

在研發人員流動情形方面，107 年度部門異動 369 人為公司組織調整，將原屬於製造部門試產的人員，調整至研發部門； 107~109 年度及 110 年截至 6 月底離職率分別為 5.76%、5.79%、5.99%及 3.13%，除 108 年離職中有 3 人、109 年離職中有 1 人及 110 年第一季離職中有 1 人為主管級以外，其餘離職人員皆為非主管級，離職原因主要係為個人職涯規劃或家庭因素等，該等離職人員交接程序皆已辦妥，業務上之銜接亦無中斷情形，故尚不足以對該公司及其子公司研發計畫及進程造成顯著影響，而該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至 6 月底新進人數皆足以支應離職人數，研發組織人力配置尚維持穩定。

該公司及其子公司研發人員在職期間之相關研發成果皆屬該公司所擁有，且對於所有研發人員均簽訂工作契約，其內容主要規範機密資訊之保密義務，為避免人員流動造成研發中斷風險，該公司及其子公司對於研究計畫、研發過程及結果皆有完整之記錄保存且訂定相關研發循環內控管理之，對於研發成功之產品基

於智慧財產權，亦申請專利保護，故人員異動對於該公司及其子公司並無技術傳承困難之情事。整體而言，研發人員之流動尚不致對該公司及其子公司研發部門之運作及公司整體營運產生重大之影響。

(3)最近期及最近三個會計年度研發費用

單位：新臺幣仟元

項目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
研發費用	3,453,483	2,962,370	3,234,765	927,399
當年度營業收入淨額	49,913,779	35,897,121	45,684,615	13,239,060
占當年度營收淨額比率	6.92%	8.25%	7.08%	7.01%

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至 3 月底研發費用分別為 3,453,483 仟元、2,962,370 仟元、3,234,765 仟元及 927,399 仟元，占各年度營業收入淨額之比率分別為 6.92%、8.25%、7.08%及 7.01%，研發費用主要為研發人員薪資、獎金、設計修改及測試相關專業服務費、製程技術改善費、電腦使用費、相關設備之折舊、耗材費等支出。108 年度研發費用金額較 107 年度減少 491,113 仟元，主係因該公司及其子公司 108 年度因邏輯產品之需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，當年度營業收入較 107 年度下降，使獎金等帳列薪資費用減少且員工及董監酬勞減少，故 108 年度研發費用占當年度營收淨額比率較高；109 年研發費用金額較 108 年度增加 272,395 仟元，主係因該公司及其子公司業績成長，調增研發人員薪資、發放獎金增加及董監和員工酬勞增加所致；110 年第一季研究發展費用相較去年同期增加 175,861 仟元，主係因業績成長而薪資費用、員工酬勞估列數增加及專業服務費、製程及技術改善費及電腦使用費增加所致。綜上，該公司及其子公司最近三年度及最近期研發費用占年度營業收入淨額約 6.92%~8.25%，除 108 年度因營收減少，致研發費用占營收比重拉高，其餘期間之研發費用占各年度營收淨額比率約為 7%，顯示該公司及其子公司為維持於半導體業製造業的競爭力，致力於研發人員的培養投入以及生產技術的開發與產品研究。該公司及其子公司最近三年度及 110 年第一季研發費用之變動情形，尚無重大異常之情事。

(4)重要研發成果

該公司及其子公司自成立以來，即不斷要求提升自身研發能力並致力於各項產品及製程技術之開發，該公司及其子公司除原有產品之效能及製程改良外，並持續投入新產品之開發，此外亦配合客戶之需求，由研發團隊與客戶共同設計研發產品，以原有製程再改善與產品再精進為目標。茲將該公司及其子公司最近三年度之重要研發成果及相關內容列示如下：

年度	內容說明	應用於
107 年度	55nm 1.2V/6V/32V	顯示驅動 IC
	180nm PMIC Porting in	電源管理 IC
	1200V IGBT Porting in	分離式元件
	0.15um DDI 1.8V/9V/18V	顯示驅動 IC
	0.11um eFlash & 0.11um EEPROM 6V	嵌入式非揮發性記憶體產品
108 年度	55nm DDI 1.2V/8V/20V	顯示驅動 IC
	40nm LOGIC 1.2V/2.5V	邏輯 IC 產品
	80nm DDI 1.2V/6V/32V	顯示驅動 IC
	0.15um DDI 3.3V/9V/18V	顯示驅動 IC
	Double Gate 30~40V	分離式元件
109 年度	55nm eFlash 1.2V/2.5V/5V	嵌入式非揮發性記憶體產品
	NOR48	快閃記憶體產品
	F38/F25 客製化 DRAM 與邏輯產品堆疊之技術驗證	1.邊緣運算、挖礦 2.high frame-rate CIS, Global Shutter
	0.65um UMOS	分離式元件

資料來源：該公司及其子公司提供

3.說明主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司及其子公司提供客戶自行研發之 IP，並與多家業界領先的矽智財服務、IP 供應商合作，向客戶提供從 0.35 微米到 55 奈米工藝平台經過矽驗證和優化的單元庫、IP，包括標準單元庫、IO 庫、記憶體模塊、編譯器、嵌入式非揮發記憶體 IP 等，滿足客戶對各種 IP 及晶片設計的需求。藉由配合客戶之需求，由研發團隊與客戶共同設計研發產品進行技術上之交流，必要時亦與大學或研究機構進行合作計畫，直接或間接提升公司技術能力，該公司及其子公司每年均持續投入研發資源，進行專案規劃及新產品開發，及長期累積豐富的實務經驗。依性質彙整如下表：

類別	合作對象	合約技術主要內容	技術報酬支付方式及金額
技術報酬金	財團法人工業技術研究院	製程開發	依合約
	學校	製程開發	依合約
	業界領先的矽智財服務及 IP 供應商	技術開發	依合約
權利金	業界領先的矽智財服務及 IP 供應商	製造一般晶圓之權利金	支付權利金方式如下： 1.依合約約定期間定額支付 2.依合約約定特定品項之出貨量乘以約定比例

類別	合作對象	合約技術主要內容	技術報酬支付方式及金額
		製造特定產品之權利金	支付權利金金額為依合約約定特定品項之出貨量乘以約定比例

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季權利金費用分別為 644,359 仟元、611,008 仟元 486,061 仟元及 144,664 仟元，分別占營業成本 1.86%、1.86%、1.40%及 1.64%。

4.研發工作未來發展方向

該公司及其子公司主要產品為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，未來產品開發方向係沿用雙主軸晶圓代工能力的優勢，發展產品技術，專注客製化產品，並發展獨步全球的與邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體製造技術；製程與技術開發方面，將朝提升製程技術能力，以提高生產效率及產品品質為工作發展方向。

產品別	未來發展方向
先進技術及模組開發	Interchip DRAM/Logic(WOW) 用成熟製程也能做 HPC(High Performance Computing)，大幅降低 HPC 成本，減緩先進製程產能壓力，成本與運算效能的優越性將使 3D InterChip 成為未來高性能、低功耗應用的主力。單位耗能所產生的運算能力(算力/耗電)超過 nVidia G4 1070(16nm 製程+GDDR5)9 倍，超過 AMD 旗艦型 GPU(7nm 製程+HBM2)6 倍。
邏輯產品代工技術開發	1. Logic/HV 從 55nm 開發推展到 40nm 和 28nm。 2. eNVM 延伸到 55nm 和 40nm。 3.CIS 則是量產推到 90nm，計劃開發 55nm。 4.Discrete 有車用半導體 IGBT、Super junction。IC 有 GaN、Panel source driver、PMIC、eFlash、OTP/MTP
記憶體產品代工技術開發	1.NOR Flash 由 90nm 進展到 48nm。 2.NAND Flash 由 40nm 推到 28nm、24nm。 3.DRAM 由 25nm 進展到 21nm、1Xnm。

5.重要技術合作契約對申請公司及其子公司之營運風險

該公司及其子公司產品技術主要是依據客戶需求自行開發及改良，最近三年度及申請年度截至最近期止，除該公司及其子公司與愛普科技股份有限公司合作開發之邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體技術的 A.I.(Artificial Intelligence)人工智慧晶片、與國際通信大廠合作開發新一代 SiGe-HBT 技術及與比利時的 imec(愛美科，又稱比利時微電子研究中心)移轉氮化鎵功率元件技術外，並無有與他人共同開發技術之技術合作並簽訂重要技術合作契約之情事，其契約內容並未有重大不利之限制條款，故對該公司及其子公司營運尚無不利之影響。

6.目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、商標權及著作權等情事，暨因應措施是否合理有效

該公司及其子公司最近三個會計年度及截至目前為止，並無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，茲將該公司及其子公司已取得、申請中之專利權及商標權列示如下：

(1)專利權

國別	發明		新式樣/設計		新型		合計	
	取得	申請中	取得	申請中	取得	申請中	取得	申請中
臺灣	399	131	—	—	3	—	402	131
美國	316	70	—	—	—	—	316	70
中國	161	128	—	—	3	—	164	128
日本	61	4	—	—	—	—	61	4
韓國	—	2	—	—	—	—	—	2
合計	937	335	—	—	6	—	943	335

資料來源：該公司及其子公司提供

A.已取得

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
1	針測卡清針方法	164303	2002/10/01-2021/09/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
2	自動化晶圓製造品管控制之方法和系統	171693	2003/01/21-2021/09/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
3	快閃記憶體的結構,製造方法及其操作方法	175995	2003/04/11-2022/04/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
4	記憶體元件之製造方法	176115	2003/04/11-2022/04/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
5	記憶體元件之結構及其製造方法	178281	2003/05/21-2022/05/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
6	快閃記憶體之製造方法	179649	2003/06/11-2022/06/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
7	快閃記憶體之製造方法	192348	2003/12/11 -2022/12/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
8	抑震裝置	I232200	2005/05/11-2023/12/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
9	半導體封裝結構及其製造方法	I233173	2005/05/21-2024/04/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
10	非揮發性記憶胞的製作方法	I233666	2005/06/01-2024/04/12	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
11	快閃記憶體的製造方法	I233665	2005/06/01-2024/02/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
12	非揮發性記憶體、非揮發性記憶體陣列及其製造方法	I233691	2005/06/01-2024/05/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
13	晶圓測試參數分析方法	I234217	2005/06/11-2022/12/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
14	彩色影像感測裝置及其製造方法	I234186	2005/06/11-2024/06/07	發明	臺灣	邏輯 IC
15	避免殘留氣體污染晶圓之設備及方法	I234801	2005/06/21-2024/05/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
16	具自動回復功能之晶圓測試裝置與晶圓測試方法	I235446	2005/07/01-2024/04/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
17	非揮發性記憶體及其製造方法	I235462	2005/07/01-2024/07/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
18	製程即時批次派工系統及其方法	I236044	2005/07/11-2024/05/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
19	管理半導體機台例行性維護之方法及相關系統	I235899	2005/07/11-2024/02/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
20	分析方法	I236080	2005/07/11-2024/08/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
21	P 型通道反及閘型快閃記憶體及其操作方法	I236141	2005/07/11-2024/11/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
22	驗證光罩的方法	I236081	2005/07/11-2024/09/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
23	製作阻障層之方法	I237327	2005/08/01-2023/11/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
24	漏氧檢測方法	I237339	2005/08/01-2023/12/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
25	利用單一蝕刻步驟形成矽尖角以及形成浮置閘極之方法	I237325	2005/08/01-2024/11/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
26	光二極體的製作方法	I237905	2005/08/11-2024/04/07	發明	臺灣	邏輯 IC
27	含氟廢水之處理方法	I238148	2005/08/21-2022/10/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
28	反及閘型快閃記憶胞列及其製造方法	I239077	2005/09/01-2023/10/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
29	快閃記憶體結構及其製作方法	I239600	2005/09/11-2023/11/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
30	半導體製程及良率分析整合即時管理方法	I239469	2005/09/11-2024/06/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
31	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I239641	2005/09/11-2024/04/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
32	廢氣排放處理系統	I239862	2005/09/21-2023/01/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
33	定位套件與定位方法	I239933	2005/09/21-2024/03/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
34	非揮發性記憶胞的製作方法	I240384	2005/09/21-2024/04/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
35	具有可變快門的曝光機台及其曝光方法	I240852	2005/10/01-2024/01/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
36	缺陷偵測及分類系統的資料分析方法	I240983	2005/10/01-2024/06/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
37	非揮發性記憶體元件及其製造方法與操作方法	I241017	2005/10/01-2025/01/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
38	溝渠式閘介電層的形成方法	I240989	2005/10/01-2025/01/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
39	非揮發記憶體的結構與製造方法	I243450	2005/11/11-2023/09/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
40	具有晶圓探針之測試系統及其顯微對準方法	I245903	2005/12/21-2022/04/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
41	多階記憶胞	I246187	2005/12/21-2023/10/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
42	活性碳過濾裝置之殺菌方法及水處理系統	I245745	2005/12/21-2023/12/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
43	快閃記憶胞及其製造方法	I246166	2005/12/21-2024/07/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
44	半導體機台之晶圓載台清潔治具	I246148	2005/12/21-2024/09/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
45	非揮發性記憶體的製造方法	I246749	2006/01/01-2025/03/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
46	非揮發性記憶體及其製造方法以及其操作方法	I246748	2006/01/01-2025/02/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
47	晶片缺陷資料庫建立方法	I247221	2006/01/11-2023/10/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
48	非揮發性記憶體之製造方法	I247391	2006/01/11-2024/09/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
49	半導體缺陷偵測方法與系統	I247376	2006/01/11-2024/12/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
50	廢氣排放處理設備	I247623	2006/01/21-2024/12/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
51	非揮發性記憶體的製造方法	I249819	2006/02/21-2025/01/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
52	防止擊穿的半導體元件的製造方法	I250580	2006/03/01-2024/11/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
53	非揮發性記憶體的製造方法	I256109	2006/06/01-2025/03/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
54	非揮發性記憶體的製造方法	I256704	2006/06/11-2025/03/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
55	半導體元件的製造方法	I256701	2006/06/11-2025/05/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
56	導線的製造方法	I263288	2006/10/01-2025/07/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
57	非揮發性記憶體及其製造方法	I263310	2006/10/01-2025/09/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
58	單次可程式化唯讀記憶體及其操作方法	I266417	2006/11/11-2024/11/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
59	快閃記憶體的製造方法	I269411	2006/12/21-2025/08/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
60	針測裝置及系統	I269399	2006/12/21-2025/11/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
61	動態隨機存取記憶體及其製造方法	I282164	2007/06/01-2025/06/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
62	廢氣排放裝置及半導體製程設備	I296818	2008/05/11-2026/03/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
63	浮置閘極與非揮發性記憶體的製造方法	I296837	2008/05/11-2026/06/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
64	非揮發性記憶體與半導體元件的製造方法	I297199	2008/05/21-2026/01/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
65	製程裝置排水回收系統及方法	I297326	2008/06/01-2023/03/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
66	字元線的形成方法與非揮發性記憶體的製造方法	I297533	2008/06/01-2026/03/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
67	應用於半導體製造之品質控制的虛擬量測預估方法與系統	I297506	2008/06/01-2026/06/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
68	非揮發性記憶體的製造方法	I297929	2008/06/11-2026/03/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
69	調整機台設定的方法、製造控制系統、及半導體製造系統	I298431	2008/07/01-2025/06/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
70	回溯記憶晶片在其母晶圓中之原位置的方法及系統	I298884	2008/07/11-2026/05/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
71	適用於半導體晶圓製造的設備校正系統與方法	I298900	2008/07/11-2026/06/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
72	靜電夾盤之使用壽命的預測方法	I298787	2008/07/11-2026/03/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
73	缺陷分類檢測方法與系統	I299538	2008/08/01-2026/06/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
74	氣體採樣裝置	I299786	2008/08/11-2026/04/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
75	非揮發性記憶體及其製造方法	I299911	2008/08/11-2026/03/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
76	隔離機台排水回收污染源之方法與系統	I300057	2008/08/21-2025/07/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
77	浮置閘極與非揮發性記憶體之製造方法	I300260	2008/08/21-2026/07/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
78	單次可程式記憶體及其製造方法	I300620	2008/09/01-2026/06/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
79	晶圓缺陷管理方法	I300887	2008/09/11-2024/06/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
80	機械手臂之無線三維位移校正系統	I301441	2008/10/01-2026/06/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
81	拋光墊及其製造方法	I301438	2008/10/01-2026/07/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
82	半導體結構與非揮發性記憶體的製造方法,以及非揮發性記憶體結構	I302021	2008/10/11-2026/06/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
83	形成氮化鈦膜的方法	I302351	2008/10/21-2022/10/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
84	電容量測之信號產生電路	I302202	2008/10/21-2026/07/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
85	反及閘型非揮發性記憶體及其製造方法與操作方法	I302741	2008/11/01-2026/06/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
86	物流設備及其感測裝置	I303465	2008/11/21-2026/04/19	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
87	半導體生產之派工整合系統及進行派工的方法	I304185	2008/12/11-2025/12/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
88	介電層的製造方法	I304231	2008/12/11-2026/07/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
89	非揮發性記憶體的製造方法	I304252	2008/12/11-2026/07/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
90	半導體製造之案件管理方法	I304557	2008/12/21-2022/03/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
91	非揮發性記憶體的製造方法	I304641	2008/12/21-2026/06/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
92	光導體覆主動像素感測器	I305059	2009/01/01-2026/07/17	發明	臺灣	邏輯 IC
93	塗佈設備及其防止接頭未拔取的裝置	I305503	2009/01/21-2026/09/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
94	半導體製造之批次控制方法與系統	I305875	2009/02/01-2025/12/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
95	影像感測器結構及其製造方法	I306307	2009/02/11-2026/09/27	發明	臺灣	邏輯 IC
96	影像感測器結構及其製造方法	I320577	2010/02/11-2026/09/19	發明	臺灣	邏輯 IC
97	具有電容器的半導體元件及其製造方法	I324389	2010/05/01-2026/09/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
98	影像感測器及其製作方法	I325634	2010/06/01-2026/11/22	發明	臺灣	邏輯 IC
99	自行對準接觸窗及其製造方法	I330398	2010/09/11-2027/01/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
100	降低加熱電極與相變化材料層間接觸面積之方法、相變化記憶裝置及其製造方法	I333273	2010/11/11-2027/05/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
101	影像感測器及其製作方法	I333692	2010/11/21-2027/02/04	發明	臺灣	邏輯 IC
102	瓶身鎖定裝置以及液體管理系統及其方法	I344669	2011/07/01-2027/06/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
103	含氟廢水之處理方法與廢水處理系統	I352069	2011/11/11-2028/01/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
104	存取非揮發性記憶體中資料的方法	I357080	2012/01/21-2028/02/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
105	積體電路與放電電路	I358067	2012/02/11-2027/12/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
106	非揮發性記憶體及其製造方法	I360203	2012/03/11-2027/10/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
107	決定非揮發性記憶體中錯誤更	I360048	2012/03/11-2028/04/23	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	正碼區塊之位元數的方法					生產製程
108	製作快閃記憶體的方法	I372448	2012/09/11-2027/08/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
109	自動化物料搬運系統及方法	I373090	2012/09/21-2028/09/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
110	承載裝置及沉積機台的監測方法	I377639	2012/11/21-2028/07/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
111	測量曝光機台之數值孔徑的方法、控片、光罩與監控曝光機台之數值孔徑的方法	I377450	2012/11/21-2028/11/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
112	取樣裝置與取樣方法	I380010	2012/12/21-2028/11/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
113	微機電系統結構及其製造方法	I388496	2013/03/11-2030/01/11	發明	臺灣	邏輯 IC
114	動態隨機存取記憶體之冠狀電容器的製程及結構	I397976	2013/06/01-2029/05/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
115	記憶體裝置以及資料讀取方法	I404076	2013/08/01-2028/01/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
116	非揮發性記憶體	I404195	2013/08/01-2029/10/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
117	非揮發性半導體記憶裝置用的分頁緩衝電路及其控制方法	I415131	2013/11/11-2029/11/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
118	具有垂直通道電晶體的動態隨機存取記憶胞及陣列	I415247	2013/11/11-2030/12/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
119	非揮發性記憶體及其製造方法	I415248	2013/11/11-2029/10/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
120	相變化記憶裝置及其製造方法	I418027	2013/12/01-2028/11/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
121	止回閥及真空系統	I420039	2013/12/21-2031/02/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
122	非揮發性記憶體元件及其製造方法	I422017	2014/01/01-2031/04/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
123	非揮發性半導體記憶裝置及其寫入方法	I426516	2014/02/11-2029/10/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
124	非揮發性半導體記憶裝置及其讀取方法	I426518	2014/02/11-2029/12/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
125	監控微影製程之方法與監控標記	I432915	2014/04/01-2028/04/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
126	風扇模組	I432943	2014/04/01-2028/12/09	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
127	非揮發性半導體記憶裝置	I433155	2014/04/01-2029/12/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
128	結合紅外線感測之環境光源感測器及其製造方法	I438917	2014/05/21-2029/11/11	發明	臺灣	邏輯 IC
129	動態隨機存取記憶體的電容器下電極的製造方法	I440166	2014/06/01-2030/08/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
130	用於 NAND 快閃記憶體技術領域的寫入方法	I451416	2014/09/01-2029/12/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
131	垂直通道電晶體陣列及其製造方法	I458068	2014/10/21-2030/08/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
132	垂直通道電晶體陣列及其製造方法	I469323	2015/01/11-2031/03/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
133	接觸窗開口的形成方法	I473205	2015/02/11-2031/11/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
134	電阻式記憶體結構及其製作方法	I473262	2015/02/11-2032/10/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
135	內部電壓調整電路、內部電壓調整方法以及半導體裝置	I482164	2015/04/21-2033/01/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
136	非揮發性半導體記憶裝置及其讀出方法	I482159	2015/04/21-2032/12/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
137	承載治具	I481737	2015/04/21-2034/08/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
138	半導體結構的製造方法	I485811	2015/05/21-2032/07/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
139	立體垂直式記憶體的製作方法	I488265	2015/06/11-2032/07/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
140	一種半導體線路製程	I488238	2015/06/11-2032/03/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
141	半導體結構及其製造方法	I490982	2015/07/01-2031/08/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
142	非揮發性半導體記憶裝置及其寫入方法	I496152	2015/08/11-2032/07/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
143	半導體記憶裝置及其 ID 碼及上位位址寫入方法	I496153	2015/08/11-2032/07/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
144	光感測器	I505455	2015/10/21-2033/09/26	發明	臺灣	邏輯 IC
145	非揮發性記憶體及其製造方法	I506768	2015/11/01-2030/12/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
146	爐管製程的派工控制方法	I506702	2015/11/01-2034/07/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
147	穿透式電子顯微鏡試片的製備方法	I506262	2015/11/01-2034/08/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
148	垂直式無電容ＤＲＡＭ記憶胞、ＤＲＡＭ陣列及其操作方法	I517307	2016/01/11-2031/08/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
149	一種半導體線路結構暨其製程	I517247	2016/01/11-2032/04/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
150	位準移位電路以及利用位準移位電路之半導體裝置	I517579	2016/01/11-2032/11/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
151	非揮發性半導體記憶裝置及其讀出方法	I517168	2016/01/11-2033/05/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
152	非揮發性記憶體裝置	I517166	2016/01/11-2033/11/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
153	結合紅外線感測功能之多波段光感測器及其製造方法	I517370	2016/01/11-2033/09/08	發明	臺灣	邏輯 IC
154	高壓靴帶式閘極驅動裝置	I521847	2016/02/11-2034/04/28	發明	臺灣	邏輯 IC
155	非揮發性記憶體及其製作方法	I525752	2016/03/11-2033/03/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
156	非揮發性半導體儲存裝置以及其控制方法	I525626	2016/03/11-2034/04/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
157	電源供應系統及電子裝置的維修方法	I525961	2016/03/11-2034/04/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
158	電阻式隨機存取記憶體	I531100	2016/04/21-2034/02/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
159	記憶體線路結構以及其半導體線路製程	I531032	2016/04/21-2033/11/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
160	晶片可靠度的測試板及其測試系統	I530702	2016/04/21-2034/12/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
161	負基準電壓產生電路及負基準電壓產生系統	I541628	2016/07/11-2035/01/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
162	三維記憶體的陣列結構及其製造方法	I542055	2016/07/11-2034/08/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
163	自動化資源傳送裝置及傳送方法	I541751	2016/07/11-2034/10/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
164	光阻回收系統及其方法	I547772	2016/09/01-2034/09/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
165	非揮發性記憶體及其製作方法	I548064	2016/09/01-2035/02/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
166	半導體裝置的製作方法	I548039	2016/09/01-2035/03/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
167	影像感測器及其製作方法	I548075	2016/09/01-2035/05/27	發明	臺灣	邏輯 IC
168	化學機械研磨裝置與方法	I547348	2016/09/01-2035/08/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
169	溝渠式橫向擴散金屬氧化半導體元件及其製造方法	I548086	2016/09/01-2035/03/11	發明	臺灣	邏輯 IC
170	介層窗製程用的溝填處理方法	I550769	2016/09/21-2035/01/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
171	曝光機台的遮光裝置	I550362	2016/09/21-2034/09/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
172	半導體晶圓、半導體晶片以及半導體裝置及其製造方法	I550749	2016/09/21-2035/01/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
173	影像感應器	I550842	2016/09/21-2035/04/08	發明	臺灣	邏輯 IC
174	半導體元件的製造方法	I550716	2016/09/21-2035/07/07	發明	臺灣	邏輯 IC
175	快閃記憶體裝置及其程式化動作的初始化方法	I550616	2016/09/21-2035/07/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
176	自動監控膜厚均勻性的方法	I550750	2016/09/21-2035/06/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
177	晶圓級動態預燒測試方法	I550293	2016/09/21-2035/09/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
178	NOR 型快閃記憶體及其製造方法	I555131	2016/10/21-2034/03/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
179	半導體元件及其製作方法	I555120	2016/10/21-2034/10/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
180	非揮發性記憶體的製造方法	I555065	2016/10/21-2034/12/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
181	快閃記憶體閘極結構及其製作方法	I555213	2016/10/21-2034/09/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
182	電阻式隨機存取記憶體結構及電阻式隨機存取記憶體的操作方法	I555246	2016/10/21-2034/11/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
183	動態記憶體測試裝置及其測試方法	I559009	2016/11/21-2034/12/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
184	隔離結構及具有其之非揮發性記憶體的製造方法	I555179	2016/10/21-2035/02/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
185	圖案化方法	I555082	2016/10/21-2035/05/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
186	半導體元件的製作方法	I555066	2016/10/21-2035/05/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
187	記憶體結構及其操作方法	I559450	2016/11/21-2034/04/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
188	快閃記憶體及其製造方法	I559459	2016/11/21-2034/12/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
189	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I559585	2016/11/21-2034/10/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
190	內部電源電壓產生電路、半導體記憶裝置及半導體裝置	I559308	2016/11/21-2035/05/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
191	半導體結構的製造方法	I559370	2016/11/21-2035/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
192	非揮發性記憶體的製造方法	I559455	2016/11/21-2035/01/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
193	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I559586	2016/11/21-2034/12/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
194	負基準電壓產生電路	I559114	2016/11/21-2035/08/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
195	半導體晶圓的金屬汙染即時監控方法	I559424	2016/11/21-2035/03/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
196	浮置閘極與非揮發性記憶胞的製造方法	I559456	2016/11/21-2035/06/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
197	快閃記憶體的製作方法	I566294	2017/01/11-2034/10/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
198	晶圓傳送盒搬運方法、橋接儲存器、以及控制裝置	I566316	2017/01/11-2034/12/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
199	非揮發性記憶體及其製造方法	I566381	2017/01/11-2034/12/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
200	能改善像素動態範圍的 CMOS 影像感應器	I566390	2017/01/11-2034/10/30	發明	臺灣	邏輯 IC
201	一種爐管製程的派工控制方法	I566064	2017/01/11-2035/06/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
202	靜態隨機存取記憶體	I566335	2017/01/11-2035/10/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
203	製程控制方法與製程控制系統	I571908	2017/02/21-2034/08/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
204	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I572073	2017/02/21-2034/09/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
205	曝光機台對準光源裝置內的模組作動監控方法及監控系統	I571710	2017/02/21-2034/12/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
206	非揮發性記憶體的製造方法	I571973	2017/02/21-2034/12/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
207	靜態隨機存取記憶體與其製造方法	I571968	2017/02/21-2034/11/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
208	半導體結構及其製造方法	I572016	2017/02/21-2035/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
209	半導體電晶體與快閃記憶體及其製造方法	I571974	2017/02/21-2035/05/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
210	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I572074	2017/02/21-2035/02/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
211	偵測微影熱點的方法	I571701	2017/02/21-2035/04/29	發明	臺灣	邏輯 IC
212	非揮發性記憶體	I572014	2017/02/21-2035/01/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
213	電壓產生電路、調節器電路、半導體記憶裝置及半導體裝置	I572135	2017/02/21-2035/08/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
214	靜態隨機存取記憶體及其製造方法	I571970	2017/02/21-2035/10/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
215	CMOS 影像感測單元及其製造方法	I572023	2017/02/21-2035/04/14	發明	臺灣	邏輯 IC
216	半導體元件及其製造方法	I572024	2017/02/21-2035/07/05	發明	臺灣	邏輯 IC
217	快閃記憶體裝置及資料抹除方法	I571879	2017/02/21-2035/07/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
218	半導體元件及其製造方法	I571938	2017/02/21-2035/10/14	發明	臺灣	邏輯 IC
219	橫向擴散金屬氧化半導體元件及其製造方法	I571939	2017/02/21-2036/01/19	發明	臺灣	邏輯 IC
220	非揮發性半導體記憶裝置與寫入方法	I581268	2017/05/01-2035/04/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
221	非揮發性記憶體及其製造方法	I581373	2017/05/01-2035/02/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
222	半導體記憶裝置	I581262	2017/05/01-2035/07/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
223	影像感測元件的光管的製造方法	I581413	2017/05/01-2035/07/16	發明	臺灣	邏輯 IC
224	物品缺陷檢測方法、影像處理	I581213	2017/05/01-2035/12/27	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	系統與電腦可讀取記錄媒體					生產製程
225	多層王冠型金屬-絕緣體-金屬電容器結構及其製作方法	I581441	2017/05/01-2035/09/07	發明	臺灣	邏輯 IC
226	電壓校正電路及電壓校正系統	I580984	2017/05/01-2035/10/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
227	半導體元件及其製作方法	I581428	2017/05/01-2035/12/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
228	曝光裝置與曝光方法	I581072	2017/05/01-2035/11/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
229	記憶體的製造方法	I581407	2017/05/01-2036/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
230	提升圖案精密度的方法	I585512	2017/06/01-2035/03/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
231	半導體裝置之控制電路及其方法	I585767	2017/06/01-2035/09/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
232	半導體記憶裝置及半導體積體電路裝置	I585772	2017/06/01-2035/07/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
233	非揮發性記憶裝置與用於非揮發性記憶裝置的寫入電路及方法	I585768	2017/06/01-2035/09/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
234	電容器結構及其製造方法	I585795	2017/06/01-2035/05/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
235	隨機動態記憶體晶片封裝結構	I585924	2017/06/01-2035/11/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
236	止逆閥及防止氣體回沖的系統	I585323	2017/06/01-2035/11/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
237	記憶體結構	I585951	2017/06/01-2035/12/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
238	相移式光罩及其製造方法	I585510	2017/06/01-2036/02/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
239	內部電源電壓輔助電路、半導體記憶裝置及半導體裝置	I592936	2017/07/21-2035/06/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
240	電晶體測試電路及方法、半導體記憶裝置以及半導體裝置	I592939	2017/07/21-2035/08/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
241	金屬氧化物金屬電容器電路及其半導體裝置	I593075	2017/07/21-2035/12/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
242	影像感測器	I593290	2017/07/21-2035/07/29	發明	臺灣	邏輯 IC
243	用於非揮發性記憶裝置的感測	I592940	2017/07/21-2035/12/27	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	電路以及非揮發性記憶裝置					生產製程
244	半導體元件及其製造方法	I593093	2017/07/21-2035/12/21	發明	臺灣	邏輯 IC
245	非揮發性記憶體及其操作方法	I593062	2017/07/21-2036/06/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
246	半導体記憶裝置	I592941	2017/07/21-2036/05/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
247	結構上的光阻圖案製程	I592759	2017/07/21-2036/06/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
248	電容器結構及其製造方法	I593120	2017/07/21-2036/07/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
249	衡量二元資料於時間等級的群聚級別的無母數分析方法	I592810	2017/07/21-2036/08/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
250	半導體裝置、測試裝置及測試系統	I598602	2017/09/11-2035/11/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
251	非揮發性半導體記憶裝置及其抹除方法	I598880	2017/09/11-2036/09/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
252	影像感測器及其製作方法	I599028	2017/09/11-2036/10/13	發明	臺灣	邏輯 IC
253	電阻式隨機存取記憶體結構	I603512	2017/10/21-2035/07/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
254	鎖存電路以及半導體記憶裝置	I603328	2017/10/21-2036/09/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
255	化學機械研磨之固定環	I602650	2017/10/21-2036/07/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
256	揮發性半導體記憶裝置、其再新控制電路及方法	I608480	2017/12/11-2036/05/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
257	半導體記憶裝置及其位址控制方法	I608478	2017/12/11-2036/09/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
258	自刷新控制裝置以及揮發性半導體記憶裝置	I608479	2017/12/11-2036/08/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
259	半導體記憶裝置	I608481	2017/12/11-2037/01/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
260	影像感測器及其製作方法	I608600	2017/12/11-2036/08/03	發明	臺灣	邏輯 IC
261	自動化晶圓交換系統以及其流程外的晶圓置換方法	I615912	2018/02/21-2035/02/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
262	壓力檢測裝置、過濾器監控系統、檢測過濾器之過濾效能之方法以及檢測是否可拆卸過濾器之方法	I615189	2018/02/21-2036/08/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
263	半導體元件	I615979	2018/02/21-2036/08/31	發明	臺灣	邏輯 IC
264	影像感測器及其製作方法	I615957	2018/02/21-2036/08/28	發明	臺灣	邏輯 IC
265	記憶體裝置	I615854	2018/02/21-2036/12/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
266	MIM 電容之結構及其製造方法	I622176	2018/04/21-2035/12/03	發明	臺灣	邏輯 IC
267	半導體元件的製造方法	I622169	2018/04/21-2037/02/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
268	影像感測器及其製作方法	I622165	2018/04/21-2037/03/05	發明	臺灣	邏輯 IC
269	記憶體結構及其製作方法	I622133	2018/04/21-2037/05/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
270	非揮發性記憶體及其存取方法	I622052	2018/04/21-2037/02/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
271	雙位元快閃記憶體記憶體結構及其製造方法	I627732	2018/06/21-2035/02/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
272	垂直式記憶體及其製作方法	I627711	2018/06/21-2037/06/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
273	影像亮度重配模組及影像亮度重配方法	I627440	2018/06/21-2037/05/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
274	半導體元件及其製造方法	I633660	2018/08/21-2037/05/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
275	快閃記憶體裝置及其更新方法	I633553	2018/08/21-2037/03/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
276	穩壓輸出裝置	I633408	2018/08/21-2037/08/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
277	統計多維變數而推算生產力的方法、統計多維變數而排程優先順序的方法與統計多維變數進行最佳化配置的方法	I639925	2018/11/01-2037/08/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
278	非揮發性記憶體裝置及對其驗證的錯誤補償方法	I640011	2018/11/01-2037/10/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
279	光罩承載平台的維護方法	I639886	2018/11/01-2037/10/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
280	積體電路晶片及其檢查方法	I639847	2018/11/01-2037/06/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
281	相移式光罩及其製作方法	I639884	2018/11/01-2037/11/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
282	非依電性儲存裝置、非依電性	I651727	2019/02/21-2037/06/06	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	記憶體積體電路及其非依電性記憶體的操作方法					生產製程
283	非揮發性記憶體結構及防止其產生程式化干擾的方法	I651835	2019/02/21-2037/03/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
284	積體電路結構及其製造方法	I651837	2019/02/21-2038/02/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
285	靜態隨機存取記憶體裝置、其冗餘電路及半導體裝置	I651729	2019/02/21-2038/05/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
286	METHOD FOR MANUFACTURING MEMORY DEVICE	6551877	2003/04/22-2022/06/11	發明	美國	DRAM 生產製程
287	EXHAUST GAS PROCESSING APPARATUS	6605141	2003/08/12-2023/03/17	發明	美國	DRAM 生產製程
288	STRUCTURE, FABRICATION AN OPERATION METHOD OF FLASH MEMORY DEVICE	6628550	2003/09/30-2022/06/14	發明	美國	DRAM 生產製程
289	METHOD OF FABRICATING FLASH MEMORY	6635533	2003/10/21-2023/03/27	發明	美國	DRAM 生產製程
290	METHOD FOR READING FLASH MEMORY WITH SILICON-OXIDE/NITRIDE/OXIDE-SILICON(SONOS) STRUCTURE	6639836	2003/10/28-2022/10/31	發明	美國	DRAM 生產製程
291	MEMORY DEVICE STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	6642111	2003/11/04-2022/07/09	發明	美國	DRAM 生產製程
292	SINGLE POLY EPROM AND METHOD FOR FORMING THE SAME	6653183	2003/11/25-2022/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
293	METHOD OF CLEANING A PROBE CARD	6659847	2003/12/09-2022/08/28	發明	美國	DRAM 生產製程
294	METHOD OF FABRICATING MEMORY DEVICE	6696350	2004/02/24-2022/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程
295	MANUFACTURING METHOD OF FLASH MEMORY	6706602	2004/03/16-2022/09/20	發明	美國	DRAM 生產製程
296	STRUCTURE OF FLASH MEMORY DEVICE AND	6730959	2004/05/04-2022/10/30	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	FABRICATION METHOD THEREOF					
297	NON-VOLATILE MEMORY CELL STRUCTURE AND METHOD FOR MANUFACTURING THEREOF	6737700	2004/05/18-2023/05/13	發明	美國	DRAM 生產製程
298	AUTOMATIC TRANSPORTING SYSTEM AND METHOD FOR OPERATING THE SAME	6745102	2004/06/01-2023/04/10	發明	美國	DRAM 生產製程
299	DUAL-BIT NITRIDE READ ONLY MEMORY CELL WITH PARASISTIC AMPLIFILER AND METHODS OF FABRICATING AND READING THE SAME	6757208	2004/06/29-2023/09/22	發明	美國	DRAM 生產製程
300	AUTOMATIC PRODUCTION QUALITY CONTROL METHOD AND SYSTEM	6766208	2004/07/20-2022/10/24	發明	美國	DRAM 生產製程
301	FLASH MEMORY WITH SELF-ALIGNED SPLIT GATE AND METHODS FOR FABRICATING AND FOR OPERATING THE SAME	6765260	2004/07/20-2023/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
302	SEMICONDUCTOR AUTOMATION SYSTEM FOR A DAILY CHECK AND METHOD THEREOF	6766213	2004/07/20-2023/04/22	發明	美國	DRAM 生產製程
303	SPLIT GATE FLASH MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6768162	2004/07/27-2023/08/05	發明	美國	DRAM 生產製程
304	STRUCTURE, FABRICATION METHOD AND OPERATION METHOD OF FLASH MEMORY	6770925	2004/08/03-2023/03/07	發明	美國	DRAM 生產製程
305	FLASH MEMORY DEVICE	6770934	2004/08/03-2023/04/03	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF					生產製程
306	FLASH MEMORY STRUCTURE AND OPERATING METHOD THEREOF	6774428	2004/08/10-2023/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
307	STRUCTURE, FABRICATION METHOD AND OPERATING METHOD FOR FLASH MEMORY	6778438	2004/08/17-2022/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
308	MEMORY DEVICES STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING THA SAME	6791136	2004/09/14-2022/07/09	發明	美國	DRAM 生產製程
309	SPLIT-GATE FLASH MEMORY STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURE	6794710	2004/09/21-2022/08/27	發明	美國	DRAM 生產製程
310	METHOD FOR DETECTING DEFECT OF SEMICONDUCTOR DEVICE	6806104	2004/10/19-2023/09/25	發明	美國	DRAM 生產製程
311	SPUTTERING APPARATUS AND MANUFACTURING METHOD OF METAL LAYER/METAL COMPOUND LAYER BY USING THEREOF	6811662	2004/11/02-2023/08/22	發明	美國	DRAM 生產製程
312	METHOD OF FORMING FLOATING GATE OF MEMORY DEVICE	6812120	2004/11/02-2024/02/26	發明	美國	DRAM 生產製程
313	FLASH MEMORY CELL	6815758	2004/11/09-2023/08/22	發明	美國	DRAM 生產製程
314	SPLIT GATE FLASH MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6821849	2004/11/23-2023/08/05	發明	美國	DRAM 生產製程
315	STRUCTURE, FABRICATION METHOD AND OPERATING METHOD FOR FLASH	6834011	2004/12/21-2022/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	MEMORY					
316	FLASH MEMORY WITH SELF-ALIGNED SPLIT GATE AND METHODS FOR FABRICATING AND FOR OPERATING THE SAME	6838343	2005/01/04-2023/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
317	FRONT OPENING UNIFIED POD AND ASSOCIATED METHOD FOR PREVENTING OUTGASSING POLLUTION	6843833	2005/01/18-2023/06/16	發明	美國	DRAM 生產製程
318	FABRICATION METHOD OF A FLASH MEMORY DEVICE	6855599	2005/02/15-2022/10/30	發明	美國	DRAM 生產製程
319	FLASH MEMORY CELL INCLUDING TWO FLOATING GATES AND AN ERASING GATE	6855598	2005/02/15-2023/04/07	發明	美國	DRAM 生產製程
320	MANAGEMENT SYSTEM OF MONITOR WAFERS	6865434	2005/03/08-2023/12/25	發明	美國	DRAM 生產製程
321	SPLIT-GATE FLASH MEMORY STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURE	6867099	2005/03/15-2022/08/27	發明	美國	DRAM 生產製程
322	TRENCH FLASH MEMORY DEVICE AND METHOD OF FABRICATING THEREOF	6870212	2005/03/22-2023/02/05	發明	美國	DRAM 生產製程
323	METHOD FOR MANUFACTURING NON-VOLATILE MEMORY CELL	6869842	2005/03/22-2023/05/13	發明	美國	DRAM 生產製程
324	METHOD OF MANUFACTURING HIGH COUPLING RATIO FLASH MEMORY HAVING SIDEWALL SPACER FLOATING GATE ELECTRODE	6875660	2005/04/05-2023/05/29	發明	美國	DRAM 生產製程
325	RETICLE TRANSFERRING SUPPORT AND TRANSFERRING METHOD	6882408	2005/04/19-2023/06/25	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	THEREOF					
326	METHOD FOR FORMING A TITANIUM NITRIDE LAYER	6893963	2005/05/17-2023/04/20	發明	美國	DRAM 生產製程
327	METHOD OF FABRICATING A FLASH MEMORY	6893918	2005/05/17-2024/05/19	發明	美國	DRAM 生產製程
328	METHOD OF ANALYZING FINAL TEST PARAMETERS	6898539	2005/05/24-2023/08/29	發明	美國	DRAM 生產製程
329	SPLIT GATE FLASH MEMORY CELL	6897521	2005/05/24-2023/09/15	發明	美國	DRAM 生產製程
330	COMPLEX MULTIVARIATE ANALYSIS SYSTEM AND METHOD	6904384	2005/06/07-2023/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程
331	FLASH MEMORY CELL, FLASH MEMORY CELL ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6911690	2005/06/28-2023/08/19	發明	美國	DRAM 生產製程
332	WAFER GRINDING APPARATUS	6910956	2005/06/28-2023/12/22	發明	美國	DRAM 生產製程
333	FLASH MEMORY STRUCTURE AND OPERATING METHOD THEREOF	6914826	2005/07/05-2023/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
334	FLASH MEMORY DEVICE STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6913974	2005/07/05-2023/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
335	SUPPORT STAND	6914732	2005/07/05-2024/08/08	發明	美國	DRAM 生產製程
336	DUMMY PROCESS AND POLISHING-PAD CONDITIONING PROCESS FOR CHEMICAL MECHANICAL POLISHING APPARATUS	6913516	2005/07/05-2024/07/16	發明	美國	DRAM 生產製程
337	SINGLE POLY EPROM AND METHOD FOR FORMING THE SAME	6917070	2005/07/12-2022/10/24	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
338	METHOD OF STABLIZING MATERIAL LAYER	6919102	2005/07/19-2023/07/08	發明	美國	DRAM 生產製程
339	METHOD OF SAMPLING CONTAMINANTS OF A SEMICONDUCTOR WAFER CARRIER	6923188	2005/08/02-2023/05/13	發明	美國	DRAM 生產製程
340	SONOS MULTI-LEVEL MEMORY CELL	6943404	2005/09/13-2023/08/05	發明	美國	DRAM 生產製程
341	METHOD AND RELATED SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR EQUIPEMENT PREVENTION MAINTENANCE MANAGEMENT	6950783	2005/09/27-2024/03/26	發明	美國	DRAM 生產製程
342	FLASH MEMORY CELL STRUCTURE	6963105	2005/11/08-2023/10/29	發明	美國	DRAM 生產製程
343	AUTO-RECOVERY WAFER TESTING APPARATUS AND WAFER TESTING METHOD	6963213	2005/11/08-2024/07/28	發明	美國	DRAM 生產製程
344	METHOD FOR ANALYZING WAFER TEST PARAMETERS	6968280	2005/11/22-2023/07/08	發明	美國	DRAM 生產製程
345	METHOD OF FABRICATING FLASH MEMORY CELL	6972260	2005/12/06-2024/05/07	發明	美國	DRAM 生產製程
346	METHOD OF FABRICATING A FLASH MEMORY	6984559	2006/01/10-2024/05/27	發明	美國	DRAM 生產製程
347	METHOD AND RELATED SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR EQUIPMENT EARLY WARNING MANAGEMENT	6999897	2006/02/14-2024/03/28	發明	美國	DRAM 生產製程
348	NAND FLASH MEMORY CELL ROW	7005699	2006/02/28-2024/01/15	發明	美國	DRAM 生產製程
349	METHOD OF BUILDING A DEFECT DATABASE	7020536	2006/03/28-2024/02/06	發明	美國	DRAM 生產製程
350	METHOD OF FABRICATING A FLASH MEMORY CELL	7029973	2006/04/18-2023/03/13	發明	美國	DRAM 生產製程
351	ASEISMATIC DEVICE	7028433	2006/04/18-2024/06/11	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
352	CAPACITY MANAGEMENT SYSTEM AND METHOD	7035704	2006/04/25-2024/11/16	發明	美國	DRAM 生產製程
353	NON-VOLATILE MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7038267	2006/05/02-2024/04/30	發明	美國	DRAM 生產製程
354	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY CELL ADAPTED FOR INTEGRATION OF DEVICES AND FOR MULTIPLE READ/WRITE OPERATIONS	7049189	2006/05/23-2024/07/16	發明	美國	DRAM 生產製程
355	FLASH MEMORY CELL, FLASH MEMORY CELL ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7057940	2006/06/06-2023/08/19	發明	美國	DRAM 生產製程
356	METHOD OF MANUFACTURING NON-VOLATILE MEMORY CELL	7060560	2006/06/13-2024/09/23	發明	美國	DRAM 生產製程
357	P-CHANNEL NAND FLASH MEMORY AND OPERATING METHOD THEREOF	7061805	2006/06/13-2025/06/06	發明	美國	DRAM 生產製程
358	METHOD OF DEFECT REVIEW	7071011	2006/07/04-2024/02/05	發明	美國	DRAM 生產製程
359	METHOD FOR FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7071061	2006/07/04-2025/09/26	發明	美國	DRAM 生產製程
360	METHOD FOR MANUFACTURING ONE-TIME ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY	7074674	2006/07/11-2025/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程
361	AUTOMATIC INTELLIGENT YIELD IMPROVING AND PROCESS PARAMETER MULTIVARIATE SYSTEM AND THE ANALYSIS METHOD THEREOF	7079677	2006/07/18-2025/03/15	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
362	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND METHOD OF MANFACTURING THE SAME	7091550	2006/08/15-2024/01/06	發明	美國	DRAM 生產製程
363	SEMICONDUCTOR PROCESS AND YIELD ANALYSIS INTEGRATED REAL-TIME MANAGEMENT METHOD	7099729	2006/08/29-2024/11/23	發明	美國	DRAM 生產製程
364	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	7102193	2006/09/05-2025/11/09	發明	美國	DRAM 生產製程
365	FLASH MEMORY CELL	7109082	2006/09/19-2024/12/21	發明	美國	DRAM 生產製程
366	MULTI-LEVEL MEMORY CELL AND FABRICATING METHOD THEREOF	7098109	2006/08/29-2023/08/05	發明	美國	DRAM 生產製程
367	METHOD OF FORMING BARRIER LAYER	7115214	2006/10/03-2024/05/13	發明	美國	DRAM 生產製程
368	METHOD OF APPLYING MICRO-PROTECTION IN DEFECT ANALYSIS	7115865	2006/10/03-2025/06/01	發明	美國	DRAM 生產製程
369	METHOD OF FABRICATING A PHOTOSENSITIVE STRUCTURE	7125738	2006/10/24-2024/10/14	發明	美國	邏輯 IC
370	INSPECTION METHODS FOR A SEMICONDUCTOR DEVICE	7132354	2006/11/07-2025/08/30	發明	美國	DRAM 生產製程
371	DEVICE AND METHOD FOR TESTING AN EXPOSURE APPARATUS	7145644	2006/12/05-2024/11/03	發明	美國	DRAM 生產製程
372	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7144774	2006/12/05-2025/08/29	發明	美國	DRAM 生產製程
373	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7148107	2006/12/12-2025/11/15	發明	美國	DRAM 生產製程
374	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD AND OPERATING METHOD THEREOF	7154142	2006/12/26-2025/06/21	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
375	MULTI-LEVEL MEMORY CELL	7164177	2007/01/16-2024/03/15	發明	美國	DRAM 生產製程
376	AUTO-RECOVERY WAFER TESTING APPARATUS AND WAFER TESTING METHOD	7164283	2007/01/16-2024/08/27	發明	美國	DRAM 生產製程
377	MANUFACTURING METHOD A FLASH MEMORY CELL ARRAY	7166513	2007/01/23-2023/08/19	發明	美國	DRAM 生產製程
378	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7166512	2007/01/23-2025/08/11	發明	美國	DRAM 生產製程
379	NON-VOLATILE MEMORY, NON-VOLATILE MEMORY ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7180128	2007/02/20-2024/11/12	發明	美國	DRAM 生產製程
380	FLASH MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7183606	2007/02/27-2024/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
381	METHOD OF FLUORIDE-CONTAINING WASTEWATER TREATMENT	7182873	2007/02/27-2025/06/17	發明	美國	DRAM 生產製程
382	METHOD OF FABRICATING A NON-VOLATILE MEMORY	7183158	2007/02/27-2025/06/08	發明	美國	DRAM 生產製程
383	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	7183607	2007/02/27-2026/04/13	發明	美國	DRAM 生產製程
384	FLASH MEMORY CELL AND FABRICATING METHOD THEREOF	7192832	2007/03/20-2024/05/20	發明	美國	DRAM 生產製程
385	WAFER DEFECT DETECTION METHODS AND SYSTEMS	7193698	2007/03/20-2025/09/05	發明	美國	DRAM 生產製程
386	METHOD FOR MANUFACTURING ANTI-PUNCH THROUGH SEMICONDUCTOR DEVICE	7195982	2007/03/27-2025/10/12	發明	美國	DRAM 生產製程
387	FLASH MEMORY	7196371	2007/03/27-2025/08/25	發明	美國	DRAM 生產製程
388	METHOD OF OPERATING P-CHANNEL MEMORY	7200040	2007/04/03-2025/10/29	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
389	METHOD OF MANUFACTURING A DUAL BIT FLASH MEMORY	7205189	2007/04/17-2025/01/25	發明	美國	DRAM 生產製程
390	METHOD FOR FORMING TRENCH GATE DIELECTRIC LAYER	7205217	2007/04/17-2025/11/21	發明	美國	DRAM 生產製程
391	SPLIT GATE FLASH MEMORY	7208796	2007/04/24-2025/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
392	DISPATCH INTEGRATION SYSTEM AND METHOD BASED ON SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	7218981	2007/05/15-2026/04/12	發明	美國	DRAM 生產製程
393	OPERATIONAL MODEL FOR SIMULATING MANUFACTURE FLOW AND SIMULATING METHOD THEREOF	7221994	2007/05/22-2025/06/23	發明	美國	DRAM 生產製程
394	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE AND NON-VOLATILE MEMORY	7226851	2007/06/05-2025/12/22	發明	美國	DRAM 生產製程
395	TOOL FOR REMOVING PARTICLES FROM RETICLE	7234196	2007/06/26-2025/06/18	發明	美國	DRAM 生產製程
396	SEMICONDUCTOR FACILITY	7235992	2007/06/26-2025/06/07	發明	美國	DRAM 生產製程
397	FLASH MEMORY CELL AND FABRICATING METHOD THEREOF	7235839	2007/06/26-2025/02/08	發明	美國	DRAM 生產製程
398	METHOD FOR FABRICATING CONDUCTIVE LINE	7235442	2007/06/26-2025/12/12	發明	美國	DRAM 生產製程
399	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	7235444	2007/06/26-2026/04/13	發明	美國	DRAM 生產製程
400	ERASING METHOD FOR NON-VOLATILE MEMORY	7239555	2007/07/03-2026/03/03	發明	美國	DRAM 生產製程
401	METHODS AND SYSTEMS	7254759	2007/08/07-2026/01/26	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	FOR SEMICONDUCTOR DEFECT DETECTION					生產製程
402	ION SAMPLING SYSTEM FOR WAFER	7255114	2007/08/14-2025/03/17	發明	美國	DRAM 生產製程
403	METHOD OF FORMING SI TIP BY SINGLE ETCHING PROCESS AND ITS APPLICATION FOR FORMING FLOATING GATE	7259051	2007/08/21-2025/09/10	發明	美國	DRAM 生產製程
404	REAL-TIME MANAGEMENT SYSTEMS AND METHODS FOR MANUFACTURING MANAGEMENT AND YIELD RATE ANALYSIS INTEGRATION	7260444	2007/08/21-2025/09/19	發明	美國	DRAM 生產製程
405	NAND FLASH MEMORY CELL ROW AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7262096	2007/08/28-2024/05/31	發明	美國	DRAM 生產製程
406	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD AND OPERATING METHOD THEREOF	7274062	2007/09/25-2026/01/24	發明	美國	DRAM 生產製程
407	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7285463	2007/10/23-2025/08/11	發明	美國	DRAM 生產製程
408	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7285450	2007/10/23-2026/01/19	發明	美國	DRAM 生產製程
409	METHODS FOR DETERMINING TOOL ASSIGNMENT PREFERENCE AND MANUFACTURING SYSTEMS USING THE SAME	7292903	2007/11/06-2026/05/11	發明	美國	DRAM 生產製程
410	PROGRAMMABLE AND ERASABLE DIGITAL SWITCH DEVICE AND FABRICATION METHOD AND OPERATING METHOD THEREOF	7291882	2007/11/06-2026/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
411	PROBE APPARATUS	7298154	2007/11/20-2026/04/26	發明	美國	DRAM 生產製程
412	METHOD FOR FABRICATING A NONVOLATILE MEMORY CELL	7309632	2007/12/18-2027/04/13	發明	美國	DRAM 生產製程
413	METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE AND WIRE WITH SILICIDE	7316956	2008/01/08-2026/03/16	發明	美國	DRAM 生產製程
414	WIRELESS 3D AUTO-OFFSET SYSTEM FOR ROBOT ARMS	7321215	2008/01/22-2026/08/09	發明	美國	DRAM 生產製程
415	METHOD OF OPERATING FLASH MEMORY CELL	7336539	2008/02/26-2024/11/25	發明	美國	DRAM 生產製程
416	FABRICATING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY	7335559	2008/02/26-2025/08/29	發明	美國	DRAM 生產製程
417	FLASH MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7335940	2008/02/26-2026/03/24	發明	美國	DRAM 生產製程
418	METHOD OF MANUFACTURING NON-VOLATILE MEMORY	7341913	2008/03/11-2026/06/29	發明	美國	DRAM 生產製程
419	PIPE TRAP	7344579	2008/03/18-2025/05/26	發明	美國	DRAM 生產製程
420	METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE	7354851	2008/04/08-2025/12/07	發明	美國	DRAM 生產製程
421	A NON-VOLATILE MEMORY	7355241	2008/04/08-2026/02/26	發明	美國	DRAM 生產製程
422	SPLIT GATE FLASH MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7358134	2008/04/15-2024/09/27	發明	美國	DRAM 生產製程
423	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICES AND PLUG	7368373	2008/05/06-2026/05/05	發明	美國	DRAM 生產製程
424	DEVICE FOR PROCESSING DISCHARGING EXHAUST GAS	7377964	2008/05/27-2026/04/26	發明	美國	DRAM 生產製程
425	METHOD OF DEFECT	7382451	2008/06/03-2026/01/05	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	INSPECTION					生產製程
426	MASK MANAGEMENT METHOD AND BAR CODE READING APPARATUS THEREOF	7389930	2008/06/24-2026/08/11	發明	美國	DRAM 生產製程
427	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7391073	2008/06/24-2026/08/03	發明	美國	DRAM 生產製程
428	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING AND OPERATING METHOD THEREOF	7391078	2008/06/24-2025/10/12	發明	美國	DRAM 生產製程
429	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7394126	2008/07/01-2026/04/26	發明	美國	DRAM 生產製程
430	PROCESS FOR REMOVING PARTICLES FROM RETICLE	7396418	2008/07/08-2024/05/07	發明	美國	DRAM 生產製程
431	NON-VOLATILE MEMORY	7397080	2008/07/08-2026/01/19	發明	美國	DRAM 生產製程
432	FABRICATING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY	7405124	2008/07/29-2026/05/08	發明	美國	DRAM 生產製程
433	PHOTOSENSITIVE DEVICE	7411276	2008/08/12-2025/01/04	發明	美國	邏輯 IC
434	METHOD OF MANAGING WAFER DEFECTS	7412090	2008/08/12-2026/06/29	發明	美國	DRAM 生產製程
435	METHOD OF MANUFACTURING WELL PICK-UP STRUCTURE OF NON-VOLATILE MEMORY	7429503	2008/09/30-2027/01/30	發明	美國	DRAM 生產製程
436	DATA TRACKING METHOD AND SYSTEM APPLIED IN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	7433750	2008/10/07-2026/12/21	發明	美國	DRAM 生產製程
437	WAFER MEASURING FIXTURE	7431260	2008/10/07-2026/08/12	發明	美國	DRAM 生產製程
438	FLASH MEMORY CELL STRUCTURE AND OPERATING METHOD	7436707	2008/10/14-2025/08/10	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	THEREOF					
439	DEVICE FOR TESTING AN EXPOSURE APPARATUS	7436489	2008/10/14-2023/06/29	發明	美國	DRAM 生產製程
440	ONE-TIME PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY AND OPERATING METHOD THEREOF	7436028	2008/10/14-2025/06/22	發明	美國	DRAM 生產製程
441	METHOD OF EVALUATING THE UNIFORMITY OF THE THICKNESS OF THE POLY-SILICON GATE LAYER	7435642	2008/10/14-2027/04/11	發明	美國	DRAM 生產製程
442	METHOD OF PIPING DEFECT DETECTION	7442561	2008/10/28-2027/02/09	發明	美國	DRAM 生產製程
443	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE	7442998	2008/10/28-2026/09/26	發明	美國	DRAM 生產製程
444	ANTI-PUNCH-THROUGH SEMICONDUCTOR DEVICE	7442980	2008/10/28-2026/04/26	發明	美國	DRAM 生產製程
445	FABRICATING METHOD OF A FLASH MEMORY CELL	7445999	2008/11/04-2025/11/11	發明	美國	DRAM 生產製程
446	METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE	7445998	2008/11/04-2025/07/22	發明	美國	DRAM 生產製程
447	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7445993	2008/11/04-2026/08/17	發明	美國	DRAM 生產製程
448	NON-VOLATILE MEMORY	7446370	2008/11/04-2026/09/02	發明	美國	DRAM 生產製程
449	PROBE SYSTEM	7449902	2008/11/11-2026/04/20	發明	美國	DRAM 生產製程
450	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD AND OPERATING METHOD THEREOF	7452775	2008/11/18-2025/10/05	發明	美國	DRAM 生產製程
451	NONVOLATILE MEMORY	7462902	2008/12/09-2026/05/25	發明	美國	DRAM 生產製程
452	FABRICATING METHOD OF AN NON-VOLATILE MEMORY	7462537	2008/12/09-2026/05/30	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
453	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7485529	2009/02/03-2024/11/12	發明	美國	DRAM 生產製程
454	METHOD OF FABRICATING FLASH MEMORY CELL	7491607	2009/02/17-2024/11/25	發明	美國	DRAM 生產製程
455	ONE TIME PROGRAMMABLE MEMORY AND THE MANUFACTURING METHOD THEREOF	7491998	2009/02/17-2027/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程
456	METHOD OF MANUFACTURING A SONOS MEMORY	7514311	2009/04/07-2024/07/28	發明	美國	DRAM 生產製程
457	MULTI-LEVEL NON-VOLATILE MEMORY	7518912	2009/04/14-2027/07/10	發明	美國	DRAM 生產製程
458	NON-VOLATILE MEMORY INCLUDING ASSIST GATE	7528438	2009/05/05-2026/12/11	發明	美國	DRAM 生產製程
459	METHOD OF MANUFACTURING PHOTODIODE	7575941	2009/08/18-2025/04/10	發明	美國	邏輯 IC
460	IMAGE SENSOR STRUCTURE WITH RECESSED SEPARATOR LAYER	7638799	2009/12/29-2027/02/15	發明	美國	邏輯 IC
461	OPERATING METHOD OF ONE-TIME PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY	7663904	2010/02/16-2025/08/03	發明	美國	DRAM 生產製程
462	IMAGE SENSOR AND FABRICATION METHOD THEREOF	7671385	2010/03/02-2028/04/25	發明	美國	邏輯 IC
463	IMAGE SENSOR AND FABRICATION METHOD THEREOF	7679157	2010/03/16-2026/11/14	發明	美國	邏輯 IC
464	MEMORY PROGRAMMING METHOD AND DATA ACCESS METHOD	7778087	2010/08/17-2029/03/23	發明	美國	DRAM 生產製程
465	PHASE CHANGE MEMORY DEVICES AND METHODS FOR FABRICATING THE	7855378	2010/12/21-2028/02/04	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	SAME					
466	METHOD FOR PROGRAMMING A MEMORY STRUCTURE	7855918	2010/12/21-2029/06/04	發明	美國	DRAM 生產製程
467	INTEGRATED CIRCUITS AND DISCHARGE CIRCUITS	7903470	2011/03/08-2029/07/10	發明	美國	DRAM 生產製程
468	JUNCTION-FREE NAND FLASH MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	7915660	2011/03/29-2029/05/19	發明	美國	DRAM 生產製程
469	MOBILE PHONE ACCESSING SYSTEM AND RELATED STORAGE DEVICE	7937072	2011/05/03-2030/01/15	發明	美國	邏輯 IC
470	PROCESS FOR FABRICATING CROWN CAPACITORS OF DRAM AND CAPACITOR STRUCTURE	7951668	2011/05/31-2029/04/13	發明	美國	DRAM 生產製程
471	METHOD FOR PROGRAMMING A MEMORY STRUCTURE	7952934	2011/05/31-2028/06/24	發明	美國	DRAM 生產製程
472	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND METHOD OF READING THE SAME	8068362	2011/11/29-2030/06/07	發明	美國	DRAM 生產製程
473	PAGE BUFFER CIRCUIT FOR ELECTRICALLY REWRITABLE NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND CONTROL METHOD	8081522	2011/12/20-2030/07/30	發明	美國	DRAM 生產製程
474	MEMORY DEVICE AND DATA READING METHOD	8131954	2012/03/06-2030/06/05	發明	美國	DRAM 生產製程
475	MCP0002-METHOD OF MEASURING NUMERICAL APERTURE OF EXPOSURE MACHINE, CONTROL WAFER, PHOTOMASK, AND	8134708	2012/03/13-2030/04/29	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	METHOD OF MONITORING NUMERICAL APERTURE OF EXPOSURE MACHINE					
476	TANK-LOCKING DEVICE, SYSTEM FOR MANAGING LIQUID SUPPLY AND METHOD USING THE SAME	8140184	2012/03/20-2031/01/20	發明	美國	DRAM 生產製程
477	MCP00018-METHOD FOR MANUFACTURING MICROELECTROMECHANICAL SYSTEM STRUCTURE	8163583	2012/04/24-2030/09/16	發明	美國	邏輯 IC
478	AUTOMATED MATERIAL HANDLING SYSTEM AND METHOD	8219242	2012/07/10-2031/03/05	發明	美國	DRAM 生產製程
479	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY, AND THE METHOD THEREOF	8223541	2012/07/17-2030/08/24	發明	美國	DRAM 生產製程
480	PHASE CHANGE MEMORY DEVICES AND METHODS FOR FABRICATING THE SAME	8242034	2012/08/14-2027/10/01	發明	美國	DRAM 生產製程
481	VOLTAGE ADJUSTING CIRCUITS AND VOLTAGE ADJUSTING METHODS	8278952	2012/10/02-2031/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
482	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY	8279673	2012/10/02-2030/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
483	TANK-LOCKING DEVICE, SYSTEM FOR MANAGING LIQUID SUPPLY AND METHOD USING THE SAME	8311669	2012/11/13-2028/01/30	發明	美國	DRAM 生產製程
484	DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY CELL AND ARRAY HAVING VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR	8324682	2012/12/04-2031/02/17	發明	美國	DRAM 生產製程
485	IMAGE SENSOR AND FABRICATION METHOD	8334164	2012/12/18-2027/11/23	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	THEREOF					
486	VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	8390062	2013/03/05-2031/02/11	發明	美國	DRAM 生產製程
487	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	8421141	2013/04/16-2031/07/04	發明	美國	DRAM 生產製程
488	VERTICLE CAPACITORLESS DRAM CELL,DRAM ARRAY AND OPERATION OF THE SAME	8441053	2013/05/14-2031/08/25	發明	美國	DRAM 生產製程
489	METHOD OF MANUFACTURING A 3-D VERTICAL MEMORY	8470671	2013/06/25-2032/10/24	發明	美國	DRAM 生產製程
490	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	8502297	2013/08/06-2031/03/25	發明	美國	DRAM 生產製程
491	MICRO ELECTRONIC MECHANICAL SYSTEM STRUCTURE	8502328	2013/08/06-2030/03/11	發明	美國	邏輯 IC
492	MANUFACTURING METHOD OF VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR ARRAY	8536008	2013/09/17-2030/07/20	發明	美國	DRAM 生產製程
493	TANK-LOCKING DEVICE, SYSTEM FOR MANAGING LIQUID SUPPLY AND METHOD USING THE SAME	8539800	2013/09/24-2028/05/23	發明	美國	DRAM 生產製程
494	AMBIT LIGHT SENSOR WITH FUNCTION OF IR SENSING	8558177	2013/10/15-2031/06/22	發明	美國	邏輯 IC
495	PROGRAMMING METHOD FOR NAND FLASH MEMORY DEVICE TO REDUCE ELECTRONS IN CHANNELS	8599614	2013/12/03-2030/01/13	發明	美國	DRAM 生產製程
496	METHOD FOR FORMING CONTACT HOLE	8709946	2014/04/29-2032/06/20	發明	美國	DRAM 生產製程
497	METHOD OF FABRICATING	8722489	2014/05/13-2031/07/04	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE					生產製程
498	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND WRITE-IN METHOD THEREOF	8738836	2014/05/27-2031/03/30	發明	美國	DRAM 生產製程
499	FABRICATING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY	8741754	2014/06/03-2031/02/22	發明	美國	DRAM 生產製程
500	INTERNAL VOLTAGE TRIMMING CIRCUIT, METHOD THEREOF AND SEMICONDUCTOR CURCUIT DEVICE COMPRISING THE SAME	8754703	2014/06/17-2032/11/05	發明	美國	DRAM 生產製程
501	VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	8786014	2014/07/22-2031/08/31	發明	美國	DRAM 生產製程
502	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND READOUT METHOD THEREOF	8824206	2014/09/02-2032/12/26	發明	美國	DRAM 生產製程
503	METHOD FOR FABRICATING BOTTOM ELECTRODE OF CAPACITORS OF DRAM	8846485	2014/09/30-2031/05/16	發明	美國	DRAM 生產製程
504	PROCESS FOR SEMICONDUCTOR CIRCUIT	8883636	2014/11/11-2033/01/26	發明	美國	DRAM 生產製程
505	METHOD OF FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	8895386	2014/11/25-2032/11/21	發明	美國	DRAM 生產製程
506	SEMICONDUCTOR STRUCTURE	8907395	2014/12/09-2032/06/10	發明	美國	DRAM 生產製程
507	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	8921819	2014/12/30-2033/02/13	發明	美國	DRAM 生產製程
508	METHOD OF FORMING SEMICONDUCTOR	8,980,703	2015/03/17-2031/09/25	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	STRUCTURE					
509	METHOD FOR FABRICATING RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY	8999809	2015/04/07-2032/11/13	發明	美國	DRAM 生產製程
510	NONVOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND WRITE-IN METHOD THEREOF	9064580	2015/06/23-2033/05/12	發明	美國	DRAM 生產製程
511	LEVEL SHIFT CIRCUIT AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING LEVEL SHIFT CIRCUIT	9076529	2015/07/07-2033/04/16	發明	美國	DRAM 生產製程
512	NONVOLATILE SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF	9076546	2015/07/07-2034/02/24	發明	美國	DRAM 生產製程
513	SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND WRITING METHOD OF ID CODES AND UPPER ADDRESSES	9082469	2015/07/14-2033/08/22	發明	美國	DRAM 生產製程
514	MULTI-WAVE BAND LIGHT SENSOR COMBINED WITH FUNCTION OF IR SENSING AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	9136301	2015/09/15-2030/09/26	發明	美國	邏輯 IC
515	LIGHT SENSOR	9142583	2015/09/22-2033/11/26	發明	美國	邏輯 IC
516	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND READING-OUT METHOD THEREFORE	9190158	2015/11/17-2033/11/04	發明	美國	DRAM 生產製程
517	SEMICONDUCTOR CIRCUIT STRUCTURE AND PROCESS OF MAKING THE SAME	9196623	2015/11/24-2034/01/12	發明	美國	DRAM 生產製程
518	PROGRAMMING METHOD FOR NAND FLASH MEMORY DEVICE TO REDUCE ELECTRONS IN CHANNELS	9214242	2015/12/15-2029/04/30	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
519	MEMORY CIRCUIT STRUCTURE AND SEMICONDUCTOR PROCESS FOR MANUFACTURING THE SAME	9245766	2016/01/26-2034/05/19	發明	美國	DRAM 生產製程
520	INTERNAL POWER VOLTAGE GENERATING CIRCUIT, SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE	9275749	2016/03/01-2035/05/21	發明	美國	DRAM 生產製程
521	IMAGE SENSOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9276026	2016/03/01-2035/07/24	發明	美國	邏輯 IC
522	NEGATIVE REFERENCE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT AND NEGATIVE REFERENCE VOLTAGE GENERATING SYSTEM USING THE SAME	9285821	2016/03/15-2034/10/14	發明	美國	DRAM 生產製程
523	SEMICONDUCTOR MEMORY APPARATUS AND SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT APPARATUS	9293227	2016/03/22-2035/07/13	發明	美國	DRAM 生產製程
524	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	9305977	2016/04/05-2034/12/25	發明	美國	DRAM 生產製程
525	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	9318703	2016/04/19-2034/12/08	發明	美國	DRAM 生產製程
526	METHOD OF FABRICATING FLASH MEMORY	9318396	2016/04/19-2035/04/22	發明	美國	DRAM 生產製程
527	GAP FILL TREATMENT FOR VIA PROCESS	9368396	2016/06/14-2035/04/21	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
528	HIGH VOLTAGE BOOTSTRAP GATE DRIVING APPARATUS	9379696	2016/06/28-2034/06/28	發明	美國	邏輯 IC
529	FLASH MEMORY APPARATUS AND DATA ERASING METHOD THEREOF	9384844	2016/07/05-2035/09/09	發明	美國	DRAM 生產製程
530	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9391271	2016/07/12-2035/03/27	發明	美國	DRAM 生產製程
531	CMOS IMAGE SENSOR UNIT AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	9391115	2016/07/12-2035/06/16	發明	美國	邏輯 IC
532	IMAGE SENSOR	9391107	2016/07/12-2035/04/29	發明	美國	邏輯 IC
533	MANUFACTURING METHOD OF STRIP-SHAPED CONDUCTIVE STRUCTURES AND NON-VOLATILE MEMORY CELL	9390931	2016/07/12-2035/07/30	發明	美國	DRAM 生產製程
534	SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE WITH ONO STACK	9397183	2016/07/19-2035/01/22	發明	美國	DRAM 生產製程
535	NEGATIVE REFERENCE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT AND SYSTEM THEREOF	9397562	2016/07/19-2035/05/21	發明	美國	DRAM 生產製程
536	METHOD OF MANUFACTURING ISOLATION STRUCTURE AND NON-VOLATILE MEMORY WITH THE ISOLATION STRUCTURE	9406784	2016/08/02-2035/04/21	發明	美國	DRAM 生產製程
537	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY STRUCTURE AND METHOD FOR OPERATING RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY	9419053	2016/08/16-2035/01/21	發明	美國	DRAM 生產製程
538	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY	9424934	2016/08/23-2035/02/18	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	DEVICE AND WRITING METHOD THEREOF					
539	FLASH MEMORY STRUCTURE AND METHOD OF MAKING THE SAME	9437600	2016/09/06-2035/04/14	發明	美國	DRAM 生產製程
540	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9437715	2016/09/06-2035/04/28	發明	美國	DRAM 生產製程
541	FLASH MEMORY APPARATUS AND INITIALIZATION METHOD FOR PROGRAMMING OPERATION THEREOF	9437311	2016/09/06-2035/08/31	發明	美國	DRAM 生產製程
542	MEMORY STRUCTRUE AND OPERATION METHOD THEREOF	9461156	2016/10/04-2034/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
543	PATTERNING METHOD	9460933	2016/10/04-2035/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
544	MANUFACTURING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY	9466605	2016/10/11-2035/01/21	發明	美國	DRAM 生產製程
545	METHOD OF FORMING STAIR-STEP STRUCTURE IN 3-D NON-VOLATILE MEMORY	9466522	2016/10/11-2035/03/12	發明	美國	DRAM 生產製程
546	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	9478741	2016/10/25-2034/12/08	發明	美國	DRAM 生產製程
547	STATIC RANDOM ACCESS MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9478552	2016/10/25-2035/05/08	發明	美國	DRAM 生產製程
548	MOM CAPACITOR CIRCUIT AND SEMICONDUCTOR DEVICE THEREOF	9484341	2016/11/01-2035/10/21	發明	美國	DRAM 生產製程
549	STATIC RANDOM ACCESS	9484349	2016/11/01-2035/10/28	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	MEMORY					生產製程
550	METHOD OF MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR DEVICE	9490349	2016/11/08-2035/07/28	發明	美國	DRAM 生產製程
551	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	9496418	2016/11/15-2035/05/05	發明	美國	DRAM 生產製程
552	NEGATIVE REFERENCE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT	9502969	2016/11/22-2035/08/06	發明	美國	DRAM 生產製程
553	METHOD OF DETECTING PHOTOLITHOGRAPHIC HOTSPOTS	9508138	2016/11/29-2035/06/18	發明	美國	邏輯 IC
554	NON-VOLATILE MEMORY APPARATUS AND WRITING CIRCUIT AND METHOD FOR NON-VOLATILE MEMORY APPARATUS	9530507	2016/12/27-2035/09/09	發明	美國	DRAM 生產製程
555	SEMICONDUCTOR TRANSISTOR AND FLASH MEMORY, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9536890	2017/01/03-2035/04/17	發明	美國	DRAM 生產製程
556	VOLTAGE GENERATING CIRCUIT AND REGULATOR CIRCUIT FOR PRECISELY CONTROL PREDETERMINED HIGH VOLTAGE	9537398	2017/01/03-2035/07/14	發明	美國	DRAM 生產製程
557	MANUFACTURING METHOD OF VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR ARRAY	9576963	2017/02/21-2031/05/28	發明	美國	DRAM 生產製程
558	INTERNAL POWER SUPPLY VOLTAGE AUXILIARY CIRCUIT, SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE	9589657	2017/03/07-2035/06/23	發明	美國	DRAM 生產製程
559	METHOD OF MANUFACTURING	9613995	2017/04/04-2035/09/25	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	SEMICONDUCTOR DEVICE					
560	METHOD FOR FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY WITH ONO STACK	9620368	2017/04/11-2035/01/22	發明	美國	DRAM 生產製程
561	IMAGE SENSOR DEVICE	9620544	2017/04/11-2035/09/07	發明	美國	邏輯 IC
562	CAPACITOR STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	9627468	2017/04/18-2035/08/21	發明	美國	DRAM 生產製程
563	SEMICONDUCTOR DEVICE CONTROL CIRCUIT AND METHOD THEREOF	9640272	2017/05/02-2035/08/06	發明	美國	DRAM 生產製程
564	VOLATILE SEMICONDCUTOR MEMORY DEVICE, REFRESH CONTROL CIRCUIT AND METHOD THEREOF	9653142	2017/05/16-2036/04/29	發明	美國	DRAM 生產製程
565	SEMICONDUCTOR DEVICE	9679934	2017/06/13-2035/09/25	發明	美國	邏輯 IC
566	NON-VALATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND LOCATION BASED ERASURE METHODS	9704579	2017/07/11-2036/07/26	發明	美國	DRAM 生產製程
567	DISPATCH CONTROL METHOD FOR FURNACE PROCESS	9709335	2017/07/18-2036/04/01	發明	美國	DRAM 生產製程
568	MULTILAYER CROWN-SHAPED MIM CAPACITOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9735228	2017/08/15-2036/01/03	發明	美國	邏輯 IC
569	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	9780195	2017/10/03-2035/08/04	發明	美國	DRAM 生產製程
570	METHOD, IMAGE PROCESSING SYSTEM AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM FOR ITEM DEFECT INSPECTION	9811899	2017/11/07-2036/04/27	發明	美國	DRAM 生產製程
571	PROCESS CONTROL	9864363	2018/01/09-2036/07/02	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	METHOD AND PROCESS CONTROL SYSTEM					生產製程
572	SEMICONDUCTOR MEMORY APPARATUS	9865327	2018/01/09-2037/03/28	發明	美國	DRAM 生產製程
573	IMAGE SENSOR AND RELATED FABRICATION METHOD	9899436	2018/02/20-2036/10/26	發明	美國	邏輯 IC
574	NONPARAMETRIC METHOD FOR MEASURING CLUSTERED LEVEL OF TIME RANK IN BINARY DATA	9904660	2018/02/27-2036/11/10	發明	美國	DRAM 生產製程
575	SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE PROVIDED WITH DRAM CELL INCLUDING TWO TRANSISTORS AND COMMON CAPACITOR	10020311	2018/07/10-2037/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
576	VOLTAGE REGULATION DEVICE CAPABLE OF STABILIZING OUTPUT VOLTAGE	10048717	2018/08/14-2037/12/07	發明	美國	DRAM 生產製程
577	POWER CONTROL CIRCUIT AND LOGIC CIRCUIT DEVICE HAVING THE SAME	10082820	2018/09/25-2038/01/09	發明	美國	DRAM 生產製程
578	RECONFIGURING IMAGE BRIGHTNESS MODULE AND RELATED METHOD	10088753	2018/10/02-2037/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
579	非挥发性存储器的制造方法	387956	2008/04/02-2025/04/18	發明	中國	DRAM 生產製程
580	防止击穿的半导体元件的制造方法	390994	2008/04/16-2025/04/18	發明	中國	DRAM 生產製程
581	沟槽式栅介电层的形成方法	469584	2009/02/11-2025/04/18	發明	中國	DRAM 生產製程
582	动态随机存取存储器及其制造方法	471664	2009/02/18-2025/08/16	發明	中國	DRAM 生產製程
583	探针测量装置及系统	582094	2009/12/23-2026/01/19	發明	中國	DRAM 生產製程
584	图像传感器结构及其制造方法	582716	2009/12/23-2026/12/18	發明	中國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
585	图像传感器及其制作方法	587759	2010/01/06-2026/12/19	發明	中國	邏輯 IC
586	相变存储装置及其制造方法	595042	2010/01/27-2027/05/15	發明	中國	DRAM 生產製程
587	相变化存储器及其制造方法	634309	2010/06/09-2027/09/24	發明	中國	DRAM 生產製程
588	具有电容器的半导体器件及其制造方法	650509	2010/07/21-2026/11/01	發明	中國	DRAM 生產製程
589	制作快闪存储器的方法	627788	2010/06/02-2027/09/29	發明	中國	DRAM 生產製程
590	自行对准接触窗及其制造方法	690530	2010/10/20-2027/01/30	發明	中國	DRAM 生產製程
591	图像传感器及其制作方法	692279	2010/10/27-2027/03/22	發明	中國	邏輯 IC
592	瓶身锁定装置以及液体管理系统及其方法	7048882	2010/12/01-2027/08/06	發明	中國	DRAM 生產製程
593	偏轴光源、遮光板及以单次曝光定义不同形态图案的方法	755745	2011/04/06-2028/09/22	發明	中國	DRAM 生產製程
594	集成电路与放电电路	778187	2011/05/11-2028/02/04	發明	中國	DRAM 生產製程
595	元件的制造方法	809292	2011/07/20-2028/09/23	發明	中國	DRAM 生產製程
596	风扇模块	853693	2011/10/19-2029/02/03	發明	中國	DRAM 生產製程
597	存储器装置以及数据读取方法	882543	2011/12/21-2028/02/03	發明	中國	DRAM 生產製程
598	存储器编程方法以及数据存取方法	881115	2011/12/21-2028/02/03	發明	中國	DRAM 生產製程
599	动态随机存取存储器的冠状电容器的制作工艺及结构	884378	2011/12/21-2029/06/07	發明	中國	DRAM 生產製程
600	相变化存储装置及其制造方法	909529	2012/02/15-2028/12/26	發明	中國	DRAM 生產製程
601	相变化内存组件及其制造方法	1113013	2013/01/02-2029/03/27	發明	中國	DRAM 生產製程
602	非易失性存储器及其制造方法	102054844 B	2013/01/09-2029/11/10	發明	中國	DRAM 生產製程
603	光感测器	2732638	2017/12/08-2033/10/14	發明	中國	邏輯 IC
604	非易失性半导体存储装置	1132249	2013/02/06-2029/12/18	發明	中國	DRAM 生產製程
605	非易失性半导体存储装置用的	1156010	2013/03/20-2029/11/06	發明	中國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	页缓冲电路及其控制方法					生產製程
606	微機電系統結構的製造方法	1240731	2013/07/24-2030/01/28	發明	中國	邏輯 IC
607	单次可编程只读存储器及其制造方法与操作方法	CN1240731	2013/06/12-2030/08/03	發明	中國	DRAM 生產製程
608	垂直沟道晶体管阵列及其制造方法	1278618	2013/09/25-2030/09/17	發明	中國	DRAM 生產製程
609	NAND 闪存装置的编程方法	1440777	2014/07/16-2029/04/30	發明	中國	DRAM 生產製程
610	具有垂直沟道晶体管的动态随机存取存储单元及阵列	1487741	2014/09/24-2030/12/28	發明	中國	DRAM 生產製程
611	动态随机存取存储器的电容器下电极的制造方法	1512524	2014/11/05-2030/09/14	發明	中國	DRAM 生產製程
612	非易失性存储器元件及其制造方法	1613665	2015/03/25-2031/04/28	發明	中國	DRAM 生產製程
613	半導體結構及其製造方法	102956560	2015/04/15-2032/02/02	發明	中國	DRAM 生產製程
614	垂直沟道晶体管阵列及其制造方法	1652580	2015/04/29-2031/04/07	發明	中國	DRAM 生產製程
615	立体垂直式存储器的制作方法	1838469	2015/11/18-2032/07/26	發明	中國	DRAM 生產製程
616	半导体线路制作工艺	1838573	2015/11/18-2032/05/11	發明	中國	DRAM 生產製程
617	半导体元件的制造方法	1953726	2016/02/17-2022/07/12	發明	中國	DRAM 生產製程
618	内部电压调整电路，内部电压调整方法以及半导体装置	2044370	2016/04/27-2033/02/05	發明	中國	DRAM 生產製程
619	一種半導體電路結構及其製程	2083999	2016/05/25-2032/05/11	發明	中國	DRAM 生產製程
620	半导体存储装置及其 ID 码及上位地址写入方法	2083219	2016/05/25-2032/08/10	發明	中國	DRAM 生產製程
621	结合红外线感测功能的多波段光感器及其制造方法	104425644 B	2016/08/17-2033/09/09	發明	中國	邏輯 IC
622	半导体结构的制造方法	103579121	2016/08/24-2032/08/02	發明	中國	DRAM 生產製程
623	非易失性半导体存储装置及其读出方法	2197062	2016/08/24-2033/01/08	發明	中國	DRAM 生產製程
624	非易失性半导体存储装置及其读出方法	2298048	2016/11/23-2033/06/07	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
625	电阻式存储器单元及其制作方法	2318098	2016/12/21-2032/10/18	發明	中國	DRAM 生產製程
626	非易失性半导体存储器装置及其写入方法	2320395	2016/12/28-2032/08/01	發明	中國	DRAM 生產製程
627	电平移位电路以及利用电平移位电路的半导体装置	2484258	2017/05/17-2032/11/23	發明	中國	DRAM 生產製程
628	电阻式随机存取存储器	2490440	2017/05/17-2034/03/18	發明	中國	DRAM 生產製程
629	互补金属氧化物半导体 影像感测单元及其制造方法	2546050	2017/07/07-2035/04/27	發明	中國	邏輯 IC
630	非挥发性存储器及其制作方法	2590480	2017/08/18-2033/04/16	發明	中國	DRAM 生產製程
631	负基准电压产生电路	2623913	2017/09/15-2035/08/27	發明	中國	DRAM 生產製程
632	非易失性半导体存储装置以及其控制方法	2667934	2017/10/24-2034/04/25	發明	中國	DRAM 生產製程
633	三维存储器的阵列结构及其制造方法	2694950	2017/11/10-2034/10/10	發明	中國	DRAM 生產製程
634	检测光刻热点的方法	2714081	2017/11/24-2035/05/14	發明	中國	邏輯 IC
635	承载治具	2751325	2017/12/22-2034/09/04	發明	中國	DRAM 生產製程
636	高压自举式栅极驱动装置	2759888	2017/12/29-2034/06/05	發明	中國	邏輯 IC
637	存储器线路结构以及其半导体线路制作工艺	2806007	2018/02/06-2033/12/06	發明	中國	DRAM 生產製程
638	工艺控制方法与工艺控制系统	2824332	2018/02/23-2034/09/02	發明	中國	DRAM 生產製程
639	负基准电压产生电路及负基准电压产生系统	2838455	2018/03/06-2035/06/11	發明	中國	DRAM 生產製程
640	存储器结构及其操作方法	2884848	2018/04/13-2034/06/05	發明	中國	DRAM 生產製程
641	晶片传送盒搬运方法、桥接储存器、以及控制装置	2884835	2018/04/13-2035/01/06	發明	中國	DRAM 生產製程
642	曝光机台的遮光装置	2991412	2018/07/06-2034/10/09	發明	中國	DRAM 生產製程
643	可进行在线叠对精度监测的测试元结构	2991269	2018/07/06-2035/02/04	發明	中國	DRAM 生產製程
644	闪存存储器的制作方法	3048395	2018/08/24-2034/11/03	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
645	电阻式随机存取存储器及其制造方法	3046492	2018/08/24-2034/11/13	發明	中國	DRAM 生產製程
646	半导体结构的制造方法	3053769	2018/08/31-2035/02/15	發明	中國	DRAM 生產製程
647	闪存存储器及其制造方法	3070168	2018/09/11-2034/12/18	發明	中國	DRAM 生產製程
648	非挥发性存储器及其制造方法	3080644	2018/09/21-2034/12/22	發明	中國	DRAM 生產製程
649	静态随机存取存储器与其制造方法	3080646	2018/09/21-2034/12/25	發明	中國	DRAM 生產製程
650	芯片可靠度的测试板及其测试系统	3090390	2018/09/28-2034/12/29	發明	中國	DRAM 生產製程
651	电阻式随机存取存储器结构及其随机存取存储器操作方法	3090384	2018/09/28-2034/12/11	發明	中國	DRAM 生產製程
652	非挥发性存储器的制造方法	3093644	2018/09/28-2035/01/22	發明	中國	DRAM 生產製程
653	止逆阀及防止气体回冲的系统	3092137	2018/09/28-2036/01/05	發明	中國	DRAM 生產製程
654	图案化方法	3125727	2018/10/26-2035/06/02	發明	中國	DRAM 生產製程
655	浮置栅极与非挥发性存储单元的制造方法	3125730	2018/10/26-2035/06/19	發明	中國	DRAM 生產製程
656	多层王冠型金属-绝缘体-金属电容器结构及其制作方法	3123040	2018/10/26-2035/10/13	發明	中國	邏輯 IC
657	NOR 型闪存存储器结构及其制造方法	3244255	2019/02/05-2034/04/15	發明	中國	DRAM 生產製程
658	炉管制作工艺的派工控制方法	3246586	2019/02/05-2034/08/26	發明	中國	DRAM 生產製程
659	电阻式随机存取存储器及其制造方法	3243948	2019/02/05-2035/02/09	發明	中國	DRAM 生產製程
660	电阻式随机存取存储器结构	3243997	2019/02/05-2035/07/21	發明	中國	DRAM 生產製程
661	半导体装置的制作方法	3242760	2019/02/05-2035/03/31	發明	中國	DRAM 生產製程
662	双位闪存存储器结构及其制造方法	3250304	2019/02/12-2035/02/15	發明	中國	DRAM 生產製程
663	半导体晶片、半导体芯片以及半导体装置及其制造方法	3283751	2019/03/08-2035/01/26	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
664	金属氧化物金属电容器电路及其半导体装置	3280736	2019/03/08-2036/01/07	發明	中國	DRAM 生產製程
665	PMI-半导体记忆装置及半导体集成电路装置	3282139	2019/03/08-2035/08/20	發明	中國	DRAM 生產製程
666	半导体存储器装置	3282788	2019/03/08-2035/12/02	發明	中國	DRAM 生產製程
667	动态存储器测试装置及其测试方法	3335359	2019/04/16-2035/01/08	發明	中國	DRAM 生產製程
668	非挥发性存储器及其制造方法	3338848	2019/04/16-2035/01/12	發明	中國	DRAM 生產製程
669	半导体晶体管与闪存存储器及其制造方法	3335880	2019/04/16-2035/05/18	發明	中國	DRAM 生產製程
670	半导体元件的制作方法	3335887	2019/04/16-2035/06/01	發明	中國	DRAM 生產製程
671	半導體元件及其製造方法	3335587	2019/04/16-2035/08/05	發明	中國	邏輯 IC
672	电容器结构及其制造方法	3335890	2019/04/16-2035/06/12	發明	中國	DRAM 生產製程
673	襯墊應力層	註		發明	中國	NA
674	化学機械研磨装置用ダミー処理方法及び研磨パッドコンディショニング方法	4125278	2008/05/16-2024/10/08	發明	日本	DRAM 生產製程
675	ＥＰＲＯＭデバイスおよびその製造方法ならびにそのプログラミング方法と読み取り方法	4143421	2008/06/20-2023/01/08	發明	日本	DRAM 生產製程
676	半導体製造装置の早期警報管理方法及びシステム	4177780	2008/08/29-2024/03/31	發明	日本	DRAM 生產製程
677	濾過装置	4195422	2008/10/03-2024/07/06	發明	日本	DRAM 生產製程
678	プローブ装置およびシステム	4422127	2009/12/11-2026/08/10	發明	日本	DRAM 生產製程
679	不揮発性半導体記憶装置とその書き込み方法	4510072	2010/05/14-2027/12/20	發明	日本	DRAM 生產製程
680	液体供給を管理するためのタンクロック装置・システムとそれを使用する方法	4702394	2011/03/18-2028/05/16	發明	日本	DRAM 生產製程
681	不揮発性半導体記憶装置とその自己テスト方法	4750813	2011/05/27-2028/03/07	發明	日本	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
682	昇圧回路の制御回路	4791560	2011/07/29-2029/04/13	發明	日本	DRAM 生產製程
683	イメージセンサー及びその製作方法	4961590	2012/04/06-2027/04/13	發明	日本	邏輯 IC
684	不揮発性半導体記憶装置とその読み出し方法	5081755	2012/09/07-2028/07/18	發明	日本	DRAM 生產製程
685	不揮発性半導体記憶装置のためのページバッファ回路とその制御方法	5086972	2012/09/14-2028/11/06	發明	日本	DRAM 生產製程
686	不揮発性半導体記憶装置	5175561	2013/01/11-2028/01/28	發明	日本	DRAM 生產製程
687	不揮発性半導体記憶装置	5231972	2013/03/29-2028/12/18	發明	日本	DRAM 生產製程
688	不揮発性半導体記憶装置とその制御方法、データ圧縮回路、データ展開回路、並びにデータ圧縮展開回路	5261059	2013/05/02-2028/07/31	發明	日本	DRAM 生產製程
689	不揮発性半導体記憶装置とそのフェイルビット数計数方法	5284737	2013/06/07-2028/09/19	發明	日本	DRAM 生產製程
690	NAND 型フラッシュメモリとその消去方法	5284909	2013/06/07-2029/08/26	發明	日本	DRAM 生產製程
691	不揮発性半導体記憶装置とその書き込み方法	5292052	2013/06/14-2028/10/21	發明	日本	DRAM 生產製程
692	半導体記憶装置並びにそのＩＤコード及び上位アドレスの書き込み方法	5337273	2013/08/09-2032/04/18	發明	日本	DRAM 生產製程
693	不揮発性半導体記憶装置とその読み出し方法	5385435	2013/10/11-2032/07/18	發明	日本	DRAM 生產製程
694	レベルシフト回路及びそれを用いた半導体デバイス	5395203	2013/10/25-2032/03/23	發明	日本	DRAM 生產製程
695	内部電圧トリミング回路及び方法、並びに半導体回路装置	5518134	2014/04/11-2032/07/02	發明	日本	DRAM 生產製程
696	不揮発性半導体記憶装置とその読み出し方法	5586666	2014/08/01-2032/08/01	發明	日本	DRAM 生產製程
697	不揮発性半導体記憶装置とその制御方法	5678151	2015/01/09-2033/09/18	發明	日本	DRAM 生產製程
698	不揮発性メモリの WL 電圧とタイミング制御方法	5745136	2015/05/15-2034/05/09	發明	日本	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
699	不揮発性半導体記憶装置とその書き込み方法	5784788	2015/07/31-2032/01/06	發明	日本	DRAM 生產製程
700	負基準電圧発生回路及び負基準電圧発生システム	5882397	2016/02/12-2034/06/05	發明	日本	DRAM 生產製程
701	不揮発性記憶装置のための書き込み回路及び方法、並びに不揮発性記憶装置	5909294	2016/04/01-2035/03/11	發明	日本	DRAM 生產製程
702	スイッチドキャパシタ回路による負電圧の基準電圧回路,	5911614	2016/04/08-2035/01/19	發明	日本	DRAM 生產製程
703	半導体装置の制御回路及び方法、並びに半導体装置	5931236	2016/05/13-2035/02/05	發明	日本	DRAM 生產製程
704	半導体記憶装置	5941577	2016/05/27-2035/05/11	發明	日本	DRAM 生產製程
705	半導体ウエハ、半導体チップ及び半導体装置とそれらの製造方法	5976055	2016/07/29-2034/08/21	發明	日本	DRAM 生產製程
706	半導体デバイスの降圧内部電源回路	5976077	2016/07/29-2034/11/14	發明	日本	DRAM 生產製程
707	承載治具	5986170	2016/08/12-2034/11/13	發明	日本	DRAM 生產製程
708	電圧発生回路、レギュレータ回路、半導体記憶装置及び半導体装置	5982510	2016/08/05-2035/02/09	發明	日本	DRAM 生產製程
709	負基準電壓發生回路	6017593	2016/10/07-2035/01/13	發明	日本	DRAM 生產製程
710	内部電源電圧補助回路、半導体記憶装置及び半導体装置	6050804	2016/12/02-2034/11/28	發明	日本	DRAM 生產製程
711	ラッチ回路及び半導体記憶装置	6069544	2017/01/06-2036/01/19	發明	日本	DRAM 生產製程
712	揮発性半導体記憶装置のリフレッシュ制御回路及び方法、並びに揮発性半導体記憶装置	6084318	2017/02/03-2036/02/22	發明	日本	DRAM 生產製程
713	半導体記憶装置及び半導体集積回路装置	6097775	2017/02/24-2035/02/16	發明	日本	DRAM 生產製程
714	チップ内部波形のモニター方法及び回路	6097797	2017/02/24-2035/08/07	發明	日本	DRAM 生產製程
715	不揮発性記憶装置のためのセンス回路及び不揮発性記憶装	6114796	2017/03/24-2035/10/05	發明	日本	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	置					
716	フラッシュメモリ構造、及びフラッシュメモリ構造を製造する方法	6131290	2017/04/21-2035/05/19	發明	日本	DRAM生產製程
717	半導体記憶装置とそのアドレス制御方法	6131357	2017/04/21-2036/03/18	發明	日本	DRAM生產製程
718	炉内プロセスのディスパッチ制御方法	6133911	2017/04/28-2035/01/22	發明	日本	DRAM生產製程
719	トランジスタテスト回路及び方法、半導体記憶装置、並びに半導体装置	6132860	2017/04/28-2035/01/22	發明	日本	DRAM生產製程
720	半導体記憶装置	6166810	2017/06/30-2036/03/08	發明	日本	DRAM生產製程
721	スイッチドキャパシタ回路及びＡＤ変換装置	6215398	2017/09/29-2036/06/22	發明	日本	DRAM生產製程
722	半導體記憶裝置	6251793	2017/12/01-2036/10/28	發明	日本	DRAM生產製程
723	半導体記憶装置	6259889	2017/12/15-2036/11/04	發明	日本	DRAM生產製程
724	ＳＲＡＭ装置のための冗長回路、ＳＲＡＭ装置、及び半導体装置	6360610	2018/06/29-2037/11/22	發明	日本	DRAM生產製程
725	電源制御回路及び電源制御回路を備えた論理回路装置	6389937	2018/08/24-2037/08/29	發明	日本	DRAM生產製程
726	NAND フラッシュメモリデバイスのプログラミング方法	4750906	2011/05/27-2029/04/30	發明	日本	DRAM生產製程
727	法拉第杯	M426862	2012/4/11-2021/10/26	新型	臺灣	DRAM生產製程
728	管路漏液監控系統	M429093	2012/5/11-2021/09/20	新型	臺灣	DRAM生產製程
729	離子收斂器及離子植佈機	M457284	2013/7/11-2023/01/28	新型	臺灣	DRAM生產製程
730	法拉第杯	2330907	2012/8/1-2021/11/17	新型	中國	DRAM生產製程
731	管路漏液監控裝置	2329169	2012/8/1-2021/09/29	新型	中國	DRAM生產製程
732	離子收斂器及離子植布機	3087125	2013/8/7-2023/02/07	新型	中國	DRAM生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
733	靜電放電保護元件	I661530	2019/06/01-2038/02/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
734	半導體裝置及其製造方法	I662687	2019/06/11-2037/04/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
735	光管結構、其製造方法及影像感測元件	I662319	2019/06/11-2037/09/26	發明	臺灣	邏輯 IC
736	用於拼接式微影製程的光罩、半色調光罩及其製作方法	I669566	2019/08/21-2038/01/17	發明	臺灣	邏輯 IC
737	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I669805	2019/08/21-2038/01/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
738	具有類光導管結構之影像感測器	I669811	2019/08/21-2038/01/31	發明	臺灣	邏輯 IC
739	開孔及其形成方法	I675399	2019/10/21-2037/08/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
740	電源控制電路以及具備電源控制電路的邏輯電路裝置	I675291	2019/10/21-2038/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
741	影像感測器及其製造方法	I675467	2019/10/21-2038/08/28	發明	臺灣	邏輯 IC
742	金屬-氧化物-金屬電容結構	I675478	2019/10/21-2038/10/29	發明	臺灣	邏輯 IC
743	記憶體結構及其製造方法	I675460	2019/10/21-2038/12/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
744	記憶體元件及其製造方法	I675453	2019/10/21-2039/02/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
745	記憶體結構及其製造方法	I675457	2019/10/21-2038/12/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
746	用於全局式快門的互補式金屬氧化物半導體影像感測器	I679755	2019/12/11-2038/10/22	發明	臺灣	邏輯 IC
747	記憶體元件及其製造方法	I679752	2019/12/11-2038/12/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
748	半導體元件的製造方法	I679690	2019/12/11-2038/10/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
749	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I679757	2019/12/11-2039/02/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
750	階梯式元件及其製造方法	I679768	2019/12/11-2039/01/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
751	研磨墊	I679083	2019/12/11-2039/01/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
752	被動元件-MCP0046-電容集成結構及其電容	I679662	2019/12/11-2039/07/31	發明	臺灣	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
753	半導體記憶裝置	I645405	2018/12/21-2037/03/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
754	CMOS 影像感測器的深溝渠隔離結構及其製造方法	I645554	2018/12/21-2037/10/05	發明	臺灣	邏輯 IC
755	溝渠式隔離結構的製造方法及高壓半導體元件	I685919	2020/02/21-2039/01/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
756	影像感測器及其製造方法	I685959	2020/02/21-2039/01/06	發明	臺灣	邏輯 IC
757	光二極體結構其製造方法	I685983	2020/02/21-2038/12/03	發明	臺灣	邏輯 IC
758	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I685951	2020/02/21-2038/10/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
759	影像感測器及其製造方法	I685958	2020/02/21-2038/12/12	發明	臺灣	邏輯 IC
760	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I685954	2020/02/21-2038/12/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
761	半導體元件及其製造方法	I685978	2020/02/21-2039/01/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
762	記憶體結構及其製造方法	I685948	2020/02/21-2039/01/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
763	工作溶液的更新方法	I685879	2020/02/21-2039/06/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
764	具有傾斜面之閘介電層及其半導體結構的製造方法	I685918	2020/02/21-2038/12/13	發明	臺灣	邏輯 IC
765	非揮發性記憶體結構	I685949	2020/02/21-2039/05/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
766	記憶體結構及其製造方法	I691098	2020/04/11-2038/11/18	發明	臺灣	邏輯 IC
767	半導體元件及其製造方法	I691096	2020/04/11-2039/01/27	發明	臺灣	邏輯 IC
768	補償非易失性記憶元件在編程時電荷流失與源極線偏置的方法	I690930	2020/04/11-2039/01/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
769	半導體製程	I691000	2020/04/11-2038/11/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
770	記憶體結構的製造方法	I691024	2020/04/11-2039/02/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
771	光罩的設計方法與半導體微影製程	I690768	2020/04/11-2039/01/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
772	基於記憶體處理器的多處理架構及其操作方法	I690848	2020/04/11-2039/03/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
773	記憶體結構及其製造方法	I691052	2020/04/11-2039/05/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
774	電流電壓轉換電路、基準電壓產生電路及非揮發性半導體存儲裝置	I690934	2020/04/11-2039/05/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
775	記憶體結構	I691051	2020/04/11-2039/05/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
776	電容單元及其製造方法	I691092	2020/04/11-2038/11/04	發明	臺灣	邏輯 IC
777	記憶體結構及其製造方法	I696266	2020/06/11-2038/12/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
778	頁緩衝電路與非揮發性儲存裝置	I696182	2020/06/11-2039/07/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
779	記憶體結構	I696285	2020/06/11-2039/05/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
780	記憶體結構及其製造方法	I696263	2020/06/11-2039/05/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
781	記憶體結構	I696247	2020/06/11-2039/01/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
782	靜態隨機存取記憶體及其製作方法	I696268	2020/06/11-2039/01/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
783	記憶體結構及其製造方法	I696272	2020/06/11-2038/11/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
784	用於帶電粒子束檢測之檢測結構及用其檢測缺陷的檢測方法	I696207	2020/06/11-2039/03/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
785	貨物搬運系統及貨物搬運方法	I695805	2020/06/11-2039/08/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
786	數位類比轉換電路、不良位元數檢測電路及非揮發性半導體存儲裝置	I696353	2020/06/11-2039/05/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
787	記憶體結構及其製造方法	I696270	2020/06/11-2039/04/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
788	具有輔助閘的快閃記憶體暨其製作方法	I696273	2020/06/11-2039/05/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
789	研磨後清潔裝置	I695741	2020/06/11-2039/09/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
790	遮蔽閘金氧半場效電晶體及其製造方法	I696288	2020/06/11-2039/07/15	發明	臺灣	邏輯 IC
791	用於雙電晶體靜態隨機存取記憶體的位元線結構	I696177	2020/06/11-2039/10/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
792	影像感測器及其製造方法	I701823	2020/08/11-2038/09/30	發明	臺灣	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
793	記憶體結構及其製造方法	I701804	2020/08/11-2039/01/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
794	晶圓夾盤裝置、晶圓形變量的量測方法及半導體製造流程	I701751	2020/08/11-2039/03/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
795	半導體結構及其製造方法	I701789	2020/08/11-2039/07/22	發明	臺灣	邏輯 IC
796	非揮發性記憶體結構	I701811	2020/08/11-2039/05/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
797	缺陷分析方法與記憶體晶片	I701429	2020/08/11-2039/09/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
798	標記的製造方法	I701797	2020/08/11-2039/07/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
799	影像感測器及其製造方法	I701842	2020/08/11-2039/08/04	發明	臺灣	邏輯 IC
800	內連線結構的製造方法	I701768	2020/08/11-2039/08/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
801	記憶體、記憶體晶片以及記憶體資料存取方法	I716299	2021/01/11-2040/03/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
802	記憶體元件及其製造方法	I720432	2021/03/01-2039/03/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
803	多層電容元件以及多層電容元件的設計方法	I720886	2021/03/01-2040/05/07	發明	臺灣	邏輯 IC
804	半導體裝置及其製造方法	I725891	2021/04/21-2040/07/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
805	半導體離子植入機的離子源頭結構	I725384	2021/04/21-2039/02/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
806	半導體封裝	I725635	2021/04/21-2039/11/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
807	失效位元數目計數電路及非揮發性半導體儲存裝置	I725799	2021/04/21-2040/03/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
808	具有表面微柱體結構的固態影像感測器暨其製作方法	I725765	2021/04/21-2040/03/09	發明	臺灣	邏輯 IC
809	半導體結構及其製造方法	I725783	2021/04/21-2040/03/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
810	影像感測模組	I725827	2021/04/21-2040/04/23	發明	臺灣	邏輯 IC
811	記憶體結構及其製造方法	I725767	2021/04/21-2040/03/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
812	電容器及其製造方法	I725769	2021/04/21-2040/03/12	發明	臺灣	邏輯 IC
813	鋁層的蝕刻後保護方法	I730419	2021/06/11-2039/09/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
814	插塞偏移的監控測試結構	I730385	2021/06/11-2039/08/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
815	絕緣閘極場效雙極性電晶體及其製造方法	I730732	2021/06/11-2040/04/21	發明	臺灣	邏輯 IC
816	絕緣閘雙極電晶體結構及其製造方法	I730814	2021/06/11-2040/06/15	發明	臺灣	邏輯 IC
817	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	I730736	2021/06/11-2040/04/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
818	記憶體結構的製造方法	I730718	2021/06/11-2040/04/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
819	記憶體元件及其製造方法	I730677	2021/06/11-2040/03/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
820	半導體元件的製造方法	I730769	2021/06/11-2040/05/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
821	互補式金氧半導體影像感測器	I730868	2021/06/11-2040/08/05	發明	臺灣	邏輯 IC
822	半導體結構以及積體電路及半導體結構	I730725	2021/06/11-2040/04/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
823	影像感測器的製造方法及對準標記結構	I730799	2021/06/11-2040/06/03	發明	臺灣	邏輯 IC
824	對準標記結構及影像感測器的製造方法	I730798	2021/06/11-2040/06/03	發明	臺灣	邏輯 IC
825	線路末端結構及其形成方法	I730869	2021/06/11-2040/08/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
826	多重圖案化方法	I730821	2021/06/11-2040/06/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
827	相位轉移光罩的製造方法	I707195	2020/10/11-2040/02/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
828	非揮發性半導體記憶體裝置的抹除控制電路、方法以及非揮發性半導體記憶體裝置	I707348	2020/10/11-2039/10/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
829	半導體結構的製造方法	I707385	2020/10/11-2039/10/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
830	資料寫入方法和儲存控制器	I707362	2020/10/11-2039/08/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
831	電路架構	I707438	2020/10/11-2039/07/18	發明	臺灣	邏輯 IC
832	電源開關控制電路及其控制方法	I707526	2020/10/11-2039/07/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
833	NAND 快閃記憶體的寫入方法	I707343	2020/10/11-2039/07/10	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
834	影像感測器及其製造方法	I707481	2020/10/11-2039/03/07	發明	臺灣	邏輯 IC
835	淺溝渠隔離結構中的針狀缺陷的監測方法	I714494	2020/12/21-2040/04/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
836	晶圓載具運輸系統	I714472	2020/12/21-2040/03/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
837	微透鏡結構及其製造方法	I714445	2020/12/21-2040/01/21	發明	臺灣	邏輯 IC
838	具有隱藏的識別碼的半導體堆疊結構	I714419	2020/12/21-2040/01/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
839	晶圓圖的辨識方法與電腦可讀取記錄媒體	I714371	2020/12/21-2039/11/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
840	影像感測器	I714266	2020/12/21-2039/09/17	發明	臺灣	邏輯 IC
841	可執行人工智慧運算的記憶體晶片及其操作方法	I714003	2020/12/21-2039/02/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
842	記憶體結構及其製造方法	I713980	2020/12/21-2039/01/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
843	半導體元件及其製造方法	I713978	2020/12/21-2039/01/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
844	記憶體結構	I713973	2020/12/21-2039/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
845	製程控制系統與方法	I713919	2020/12/21-2038/10/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
846	快閃記憶體裝置及其程式化方法	I713860	2020/12/21-2038/06/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
847	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE AND METHOD FOR PREVENTING NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE FROM GENERATING PROGRAM DISTURBANCE	10290644	2019/05/14-2037/06/14	發明	美國	DRAM 生產製程
848	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND ERROR COMPENSATION METHOD FOR VERIFYING THE SAME	10290363	2019/05/14-2038/02/26	發明	美國	DRAM 生產製程
849	ELECTROSTATIC DISCHARGE PROTECTION DEVICE	10361187	2019/07/23-2038/05/10	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
850	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10483271	2019/11/19-2038/03/05	發明	美國	DRAM 生產製程
851	STATIC RANDOM-ACCESS MEMORY DEVICE, REDUNDANT CIRCUIT THEREOF, AND SEMICONDUCTOR DEVICE	10497431	2019/12/03-2038/04/09	發明	美國	DRAM 生產製程
852	INTEGRATED CIRCUIT STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10504914	2019/12/10-2038/05/28	發明	美國	DRAM 生產製程
853	METHOD FOR MANUFACTURING MULTILAYER CROWN-SHAPED MIM CAPACITOR	10121848	2018/11/06-2036/02/26	發明	美國	邏輯 IC
854	MANUFACTURING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	10600798	2020/03/24-2038/03/05	發明	美國	DRAM 生產製程
855	IMAGE SENSOR AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	10629644	2020/04/21-2038/12/22	發明	美國	邏輯 IC
856	ION SOURCE HEAD STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR ION IMPLANTER	10658149	2020/05/19-2039/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
857	METAL-OXIDE-METAL CAPACITOR STRUCTURE	10672863	2020/06/02-2039/04/02	發明	美國	邏輯 IC
858	PAGE BUFFER CIRCUIT AND NONVOLATILE STORAGE DEVICE	10714190	2020/07/14-2039/02/20	發明	美國	DRAM 生產製程
859	DIGITAL TO ANALOG CONVERTOR, FAILURE BIT NUMBER DETECTOR AND NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR	10720932	2020/07/21-2039/07/26	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	STORAGE DEVICE					
860	FLASH MEMORY WITH ASSISTANT GATE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	10892341	2021/01/12-2039/07/23	發明	美國	DRAM 生產製程
861	MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10896910	2021/01/19-2039/05/24	發明	美國	DRAM 生產製程
862	TRENCH TRANSISTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10903203	2021/01/26-2038/11/15	發明	美國	DRAM 生產製程
863	CIRCUIT STRUCTURE	10910368	2021/02/02-2039/09/19	發明	美國	邏輯 IC
864	IMAGE SENSOR AND MANUFACTURING METHOD THEREFORE	10937819	2021/03/02-2038/11/08	發明	美國	邏輯 IC
865	MEMORY WITH PROCESSING IN MEMORY ARCHITECTURE AND OPERATING METHOD THEREOF	10990524	2021/04/27-2039/09/10	發明	美國	DRAM 生產製程
866	FAIL BIT NUMBER COUNTING CIRCUIT AND NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE	11004522	2021/05/11-2040/02/21	發明	美國	DRAM 生產製程
867	RETARGETING METHOD FOR OPTICAL PROXIMITY CORRECTION	10983429	2021/04/20-2040/08/18	發明	美國	DRAM 生產製程
868	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	10971519	2021/04/06-2039/07/10	發明	美國	DRAM 生產製程
869	MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10971501	2021/04/06-2039/07/09	發明	美國	DRAM 生產製程
870	静态随机存取存储器	3417914	2019/06/14-2035/12/09	發明	中國	DRAM 生產製程
871	半导体记忆装置	3435408	2019/06/28-2035/08/04	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
872	非易失性半导体存储装置与写入方法	3444015	2019/07/05-2035/05/04	發明	中國	DRAM 生產製程
873	半导体元件及其制作方法	3446009	2019/07/09-2035/01/08	發明	中國	DRAM 生產製程
874	电阻式随机存取存储器及其制造方法	3446015	2019/07/09-2035/02/15	發明	中國	DRAM 生產製程
875	非挥发性记忆体及其制造方法	3446020	2019/07/09-2035/03/11	發明	中國	DRAM 生產製程
876	非易失性存储装置与用于其的写入电路及方法	3446696	2019/07/09-2035/09/28	發明	中國	DRAM 生產製程
877	影像感应器	3448726	2019/07/09-2035/04/24	發明	中國	邏輯 IC
878	影像感应器	3449006	2019/07/09-2035/04/27	發明	中國	邏輯 IC
879	闪存装置及其编程操作的初始化方法	3447228	2019/07/09-2035/07/21	發明	中國	DRAM 生產製程
880	曝光机台对准光源装置内的模块作动监控方法及监控系统	3455179	2019/07/16-2035/01/16	發明	中國	DRAM 生產製程
881	负基准电压产生电路及负基准电压产生系统	3555605	2019/10/11-2035/01/19	發明	中國	DRAM 生產製程
882	非挥发性记忆体的制造方法	3551951	2019/10/11-2034/12/30	發明	中國	DRAM 生產製程
883	内部电源电压辅助电路、半导体存储装置及半导体装置	3552341	2019/10/11-2035/06/26	發明	中國	DRAM 生產製程
884	静态随机存取存储器及其制造方法	3554204	2019/10/11-2035/10/28	發明	中國	DRAM 生產製程
885	影像感测器及其制作方法	3553861	2019/10/11-2035/06/08	發明	中國	邏輯 IC
886	用于非易失性存储装置的感测电路以及非易失性存储装置	3551973	2019/10/11-2036/01/19	發明	中國	DRAM 生產製程
887	晶圆级动态预烧测试方法	3555654	2019/10/11-2035/09/22	發明	中國	DRAM 生產製程
888	半导体元件及其制作方法	3551969	2019/10/11-2036/01/07	發明	中國	DRAM 生產製程
889	内部电源电压产生电路、半导体存储装置及半导体装置	3595786	2019/11/12-2035/06/10	發明	中國	DRAM 生產製程
890	电晶管测试电路及方法、半导体记忆装置以及半导体装置	3592909	2019/11/12-2035/08/21	發明	中國	DRAM 生產製程
891	电压产生电路及调节器电路	3591620	2019/11/12-2035/08/25	發明	中國	DRAM 生產製程
892	影像感测器	3594519	2019/11/12-2035/08/20	發明	中國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
893	半导体元件及其制造方法	3592325	2019/11/12-2035/11/02	發明	中國	邏輯 IC
894	半導體裝置、測試裝置及測試系統	3592960	2019/11/12-2035/12/09	發明	中國	DRAM 生產製程
895	半导体装置的控制电路及其方法	3649549	2019/12/31-2035/10/22	發明	中國	DRAM 生產製程
896	闪存存储器栅极结构及其制作方法	3160475	2020/01/01-2034/09/23	發明	中國	DRAM 生產製程
897	电阻式随机存取存储器及其制造方法	3130733	2018/11/02-2034/09/30	發明	中國	DRAM 生產製程
898	非挥发性存储器	3174003	2018/12/07-2035/01/22	發明	中國	DRAM 生產製程
899	自动监控膜厚均匀性的方法	3159745	2018/11/23-2035/07/07	發明	中國	DRAM 生產製程
900	化学机械研磨装置与方法	3182628	2018/12/14-2035/09/11	發明	中國	DRAM 生產製程
901	半导体元件及其制造方法	3653506	2020/01/03-2036/01/06	發明	中國	邏輯 IC
902	物品缺陷检测方法、图像处理系统与计算机可读记录介质	3680466	2020/02/04-2036/02/17	發明	中國	DRAM 生產製程
903	提升圖案精密度的方法	3684745	2020/02/07-2035/03/30	發明	中國	DRAM 生產製程
904	闪存装置及数据擦除方法	3681227	2020/02/07-2035/07/17	發明	中國	DRAM 生產製程
905	横向扩散金属氧化半导体元件及其制造方法	3684544	2020/02/07-2036/02/04	發明	中國	邏輯 IC
906	影像感测器及其制作方法	3684040	2020/02/07-2036/10/28	發明	中國	邏輯 IC
907	影像感测器及其制作方法	3764788	2020/04/21-2036/09/12	發明	中國	邏輯 IC
908	半导体存储器装置及其地址控制方法	3829982	2020/04/21-2036/09/13	發明	中國	DRAM 生產製程
909	半导体存储器装置	3829280	2020/06/09-2036/10/17	發明	中國	DRAM 生產製程
910	半导体存储器装置	3829677	2020/06/09-2036/06/14	發明	中國	DRAM 生產製程
911	非挥发性存储器结构及防止其产生编程干扰的方法	3924337	2020/06/09-2037/04/28	發明	中國	DRAM 生產製程
912	鎖存電路以及半導體記憶體裝置	3918596	2020/08/04-2036/09/19	發明	中國	DRAM 生產製程
913	电容器结构及其制造方法	3918725	2020/08/04-2036/07/19	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
914	半导体存储装置	3919369	2020/08/04-2037/07/24	發明	中國	DRAM 生產製程
915	影像亮度重配模塊及影像亮度重配方法	3923153	2020/08/04-2037/06/02	發明	中國	DRAM 生產製程
916	稳压输出装置	3918741	2020/08/04-2037/09/04	發明	中國	DRAM 生產製程
917	半導體元件	4010632	2020/09/29-2036/09/12	發明	中國	邏輯 IC
918	垂直式记忆体及其制作方法	4008547	2020/09/29-2037/06/21	發明	中國	DRAM 生產製程
919	集成电路芯片及其检查方法	4008937	2020/09/29-2037/07/21	發明	中國	DRAM 生產製程
920	半导体装置及其制造方法	4082663	2020/11/10-2037/04/27	發明	中國	DRAM 生產製程
921	非易失性半导体存储设备及其擦除方法	4088488	2020/11/10-2036/09/22	發明	中國	DRAM 生產製程
922	静态随机存取存储器装置、其冗余电路及半导体装置	4089004	2020/11/10-2038/05/22	發明	中國	DRAM 生產製程
923	静电放电保护元件	4155515	2020/12/15-2038/03/06	發明	中國	DRAM 生產製程
924	结构上的光致抗蚀剂图案制作工艺	4151587	2020/12/16-2036/08/15	發明	中國	DRAM 生產製程
925	快闪存储器装置及其更新方法	4155938	2020/12/18-2037/04/20	發明	中國	DRAM 生產製程
926	自刷新控制装置以及易失性半导体存储器装置	4200382	2021/01/12-2036/09/08	發明	中國	DRAM 生產製程
927	存储器装置	4199389	2021/01/12-2036/12/23	發明	中國	DRAM 生產製程
928	非易失性存储器装置及对其验证的错误补偿方法	4206085	2021/01/15-2037/11/09	發明	中國	DRAM 生產製程
929	揮發性半導體記憶裝置、其再新控制電路及方法	4207583	2021/01/15-2036/06/07	發明	中國	DRAM 生產製程
930	非易失性存储器及其存取方法	4204972	2021/01/15-2037/03/17	發明	中國	DRAM 生產製程
931	图像传感器及其制作方法	4208354	2021/01/15-2037/03/17	發明	中國	邏輯 IC
932	CMOS 影像感测器的深沟渠隔离结构及其制造方法	4295463	2021/03/12-2037/10/19	發明	中國	邏輯 IC
933	非揮發性記憶體結構及其製造方法	4407054	2021/05/07-2038/01/12	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
934	光管结构、其制造方法及影像感测元件	4479609	2021/06/11-2037/10/12	發明	中國	邏輯 IC
935	电源开关控制电路及其控制方法	4503899	2021/06/22-2039/08/15	發明	中國	DRAM 生產製程
936	不揮発性メモリ構造およびその製造方法	6634480	2019/12/20-2038/07/10	發明	日本	DRAM 生產製程
937	パワースイッチ制御回路とその制御方法	6666985	2020/02/26-2038/11/16	發明	日本	DRAM 生產製程
938	ページバッファ回路及び不揮発性記憶装置	6677786	2020/03/17-2038/11/20	發明	日本	DRAM 生產製程
939	ＤＡ変換回路、不良ビット数検出回路及び不揮発性半導体記憶装置	6694090	2020/04/20-2029/03/01	發明	日本	DRAM 生產製程
940	不揮発性半導体記憶装置の消去制御回路及び方法、並びに不揮発性半導体記憶装置	6741811	2020/07/29-2039/03/07	發明	日本	DRAM 生產製程
941	フェイルビット数計数回路及び不揮発性半導体記憶装置	6757447	2020/09/01-2039/06/12	發明	日本	DRAM 生產製程
942	メモリプロセッサを用いた多重処理アーキテクチャ及びその動作方法	6882398	2021/05/10-2039/09/13	發明	日本	DRAM 生產製程
943	電流電圧変換回路、基準電圧発生回路及び不揮発性半導体記憶装置	6887457	2021/05/20-2039/03/01	發明	日本	DRAM 生產製程

資料來源：該公司及其子公司提供

B.申請中

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
1	相移式光罩及其製造方法	201610268778.X	2016/4/27	發明	中國	DRAM 生產製程
2	襯墊應力層	201710127453.4	2017/3/6	發明	中國	DRAM 生產製程
3	光掩膜及其制造方法以及曝光方法	201710128566.6	2017/3/6	發明	中國	DRAM 生產製程
4	光掩模及其制造方法	201710131022.5	2017/3/7	發明	中國	DRAM 生產製程
5	金属绝缘体金属元件的制造方法	201710153461.6	2017/3/15	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
6	半导体存储器装置	201710176970.0	2017/3/23	發明	中國	DRAM 生產製程
7	半導體元件及其製造方法	201710426537.8	2017/6/8	發明	中國	DRAM 生產製程
8	非易失性储存装置、非易失性存储器集成电路及操作方法	201710584841 .5	2017/7/18	發明	中國	DRAM 生產製程
9	晶圓測試多目標產能規劃系統與方法	201710822787.3	2017/9/13	發明	中國	DRAM 生產製程
10	光掩模及光掩模承载平台的维护方法	201711069037.X	2017/11/3	發明	中國	DRAM 生產製程
11	相移式光掩模及其制作方法	201711306818.6	2017/12/11	發明	中國	DRAM 生產製程
12	电源控制电路以及具备电源控制电路的逻辑电路装置	201810082394.8	2018/1/29	發明	中國	DRAM 生產製程
13	拼接式光刻製作工藝的光掩模、半色調光掩模及其制法	201810126963.4	2018/2/8	發明	中國	邏輯 IC
14	集成电路结构及其制造方法	201810203742. 2	2018/3/13	發明	中國	DRAM 生產製程
15	快闪存储器装置及其编程方法	201810735122.3	2018/7/6	發明	中國	DRAM 生產製程
16	影像感測器及其製造方法	201811066356.X	2018/9/13	發明	中國	邏輯 IC
17	影像感測器及其製造方法	201811195119.3	2018/10/15	發明	中國	邏輯 IC
18	非挥发性存储器结构及其制造方法	201811220344.8	2018/10/19	發明	中國	DRAM 生產製程
19	同轴导体结构、电容器及其制造方法	201811220366.4	2018/10/19	發明	中國	邏輯 IC
20	MCP0043-溝渠式電晶體結構及其製造方法	201811243094.X	2018/10/24	發明	中國	DRAM 生產製程
21	金属-氧化物-金属电容结构	201811323365.2	2018/11/8	發明	中國	邏輯 IC
22	半导体制作工艺	201811517666.9	2018/12/12	發明	中國	DRAM 生產製程
23	存储器结构及其制造方法	201811557539.1	2018/12/19	發明	中國	DRAM 生產製程
24	記憶體結構及其製造方法	201811588101.X	2018/12/25	發明	中國	DRAM 生產製程
25	非揮發性記憶體結構及其製造方法	201811632865.4	2018/12/29	發明	中國	DRAM 生產製程
26	影像感測器及其制造方法	201811432218.9	2019/1/11	發明	中國	邏輯 IC

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
27	静态随机存取存储器及其制作方法	201910051164.X	2019/1/18	發明	中國	DRAM 生產製程
28	影像传感器及其制造方法	201910057957.2	2019/1/22	發明	中國	邏輯 IC
29	晶片的标记方法、晶圆及晶片	201910058383.0	2019/1/22	發明	中國	DRAM 生產製程
30	半导体元件及其制造方法	201910079079.4	2019/1/28	發明	中國	DRAM 生產製程
31	存储器结构	201910096167.5	2019/1/31	發明	中國	DRAM 生產製程
32	补偿非易失存储元件编程时电荷流失与源极线偏置的方法	201910097767.3	2019/1/31	發明	中國	DRAM 生產製程
33	半导体元件及其制造方法	201910096741.7	2019/1/31	發明	中國	DRAM 生產製程
34	存储器结构及其制造方法	201910096168.X	2019/1/31	發明	中國	DRAM 生產製程
35	半导体组件及其制造方法	201910110960.6	2019/2/12	發明	中國	邏輯 IC
36	记忆体结构	201910110946.6	2019/2/12	發明	中國	DRAM 生產製程
37	光掩模的设计方法与半导体光刻制作工艺	201910110925.4	2019/2/12	發明	中國	DRAM 生產製程
38	记忆体元件及其制造方法	201910113773.3	2019/2/14	發明	中國	DRAM 生產製程
39	阶梯式元件及其制造方法	201910113794.5	2019/2/14	發明	中國	DRAM 生產製程
40	沟渠式隔离结构的制造方法及高压半导体元件	201910113762.5	2019/2/14	發明	中國	DRAM 生產製程
41	存储器结构及其制造方法	201910136912.4	2019/2/25	發明	中國	DRAM 生產製程
42	电阻式随机存取存储器及其制造方法	201910149502.3	2019/2/28	發明	中國	DRAM 生產製程
43	半导体离子注入机的离子源头结构	201910166841.2	2019/3/6	發明	中國	DRAM 生產製程
44	可执行人工智能运算的存储器芯片及其操作方法	201910216548.2	2019/3/21	發明	中國	DRAM 生產製程
45	影像感测器及其制造方法	201910231312.6	2019/3/26	發明	中國	邏輯 IC
46	晶片夹盘装置、晶片形变量的测量方法及半导体制造流程	201910231287.1	2019/3/26	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
47	基于存储器处理器的多处理架构及其操作方法	201910288360.9	2019/4/11	發明	中國	DRAM 生產製程
48	存储器结构及其制造方法	201910327486.2	2019/4/23	發明	中國	DRAM 生產製程
49	AIM SYSTEM ARCHITECTURE OPTIMIZING FOR AI PROCESSING	62/744,140	2018/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
50	MEMORY STRUCTURE	16/285,245	2019/2/26	發明	美國	DRAM 生產製程
51	METHOD FOR DESIGNING PHOTOMASK AND SEMICONDUCTOR PHOTOLITHOGRAPHY PROCESS	16/373,637	2019/4/3	發明	美國	DRAM 生產製程
52	MCP0043-溝渠式電晶體結構及其製造方法	107137446.0	2018/10/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
53	半導體元件的製造方法	107147418.0	2018/12/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
54	半導體封裝	108110759.0	2019/3/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
55	存储器结构	201910401267.4	2019/5/15	發明	中國	DRAM 生產製程
56	存储器结构及其制造方法	201910417590.0	2019/5/20	發明	中國	DRAM 生產製程
57	电流电压转换电路、基准电压产生电路及非挥发性半导体储存装置	201910444948.9	2019/5/27	發明	中國	DRAM 生產製程
58	具有辅助栅的闪存存储器及其制作方法	201910444569.X	2019/5/27	發明	中國	DRAM 生產製程
59	非挥发性存储器结构	201910449969.X	2019/5/28	發明	中國	DRAM 生產製程
60	半导体封装	201910450085.6	2019/5/28	發明	中國	DRAM 生產製程
61	THE NOVEL 3D NAND FLASH BY LATERAL RE-DISTRIBUTION FREE DESIGN	201910463347.2	2019/5/30	發明	中國	DRAM 生產製程
62	具有记忆体内运算架构的记忆体及其操作方法	201910547680.1	2019/6/24	發明	中國	DRAM 生產製程
63	标记的制造方法	201910664807.8	2019/7/23	發明	中國	DRAM 生產製程
64	电容单元及其制造方法	201910675399.6	2019/7/25	發明	中國	邏輯 IC

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
65	遮蔽柵金屬氧化物半导体场效晶体管及其制造方法	201910693360.7	2019/7/30	發明	中國	邏輯 IC
66	半导体结构及其制造方法	201910715947.3	2019/8/5	發明	中國	邏輯 IC
67	頁緩衝電路與非揮發性儲存裝置	201910723047.3	2019/8/6	發明	中國	DRAM 生產製程
68	电容集成结构及其电容	201910752390 .0	2019/8/15	發明	中國	邏輯 IC
69	数模转换器、不良位数检测器及非易失性半导体存储装置	201910757229.2	2019/8/16	發明	中國	DRAM 生產製程
70	通道全環繞半導體裝置及其製造方法	201910806551.X	2019/8/29	發明	中國	邏輯 IC
71	電路架構	201910806631.5	2019/8/29	發明	中國	邏輯 IC
72	固定環	201910821982.3	2019/9/2	發明	中國	DRAM 生產製程
73	内连线结构的制造方法	201910909759.4	2019/9/25	發明	中國	DRAM 生產製程
74	用于双晶体管静态随机存取存储器的位线结构	201910976746.9	2019/10/15	發明	中國	DRAM 生產製程
75	铝层的蚀刻后保护方法	201911042647.X	2019/10/30	發明	中國	DRAM 生產製程
76	影像传感器	201911042630.4	2019/10/30	發明	中國	邏輯 IC
77	研磨后清洁装置	201911042646.5	2019/10/30	發明	中國	DRAM 生產製程
78	半导体结构的制造方法	201911093280.4	2019/11/11	發明	中國	DRAM 生產製程
79	非易失性半导体存储器装置及其擦除控制电路、方法	201911134622.2	2019/11/19	發明	中國	DRAM 生產製程
80	半导体结构及其制造方法	202010004398.1	2020/1/3	發明	中國	邏輯 IC
81	晶圓圖的辨識方法與電腦可讀取記錄媒體	201911355190.8	2020/1/6	發明	中國	DRAM 生產製程
82	具有隐藏的识别码的半导体堆叠结构	202010040962.5	2020/1/15	發明	中國	DRAM 生產製程
83	半导体封装	202010074748.1	2020/1/22	發明	中國	DRAM 生產製程
84	半導體封裝	202010076181.1	2020/1/23	發明	中國	DRAM 生產製程
85	电容结构以及其制作方法	202010080562.7	2020/2/5	發明	中國	邏輯 IC
86	影像感測器結構及其製造方法	202010089928.7	2020/2/13	發明	中國	邏輯 IC
87	微透鏡結構及其製造方法	202010089872.5	2020/2/13	發明	中國	邏輯 IC

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
88	非揮發性記憶體元件及其製造方法	202010146226.8	2020/3/5	發明	中國	DRAM 生產製程
89	存储器结构及其制造方法	202010221969.7	2020/3/26	發明	中國	邏輯 IC
90	存储器结构及其制造方法	202010221969.7	2020/3/26	發明	中國	邏輯 IC
91	半导体元件及其制造方法	202010234917.3	2020/3/30	發明	中國	邏輯 IC
92	存储器、存储器芯片以及存储器数据存取方法	202010289049.9	2020/4/14	發明	中國	DRAM 生產製程
93	失效位数目计数电路及非易失性半导体储存装置	202010311415.6	2020/4/20	發明	中國	DRAM 生產製程
94	記憶體結構的製造方法	202010330782.0	2020/4/24	發明	中國	DRAM 生產製程
95	绝缘栅极场效双极性晶体管及其制造方法	202010376705.9	2020/5/7	發明	中國	邏輯 IC
96	記憶體元件及其製造方法	202010376547.7	2020/5/7	發明	中國	DRAM 生產製程
97	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	202010385789.2	2020/5/9	發明	中國	DRAM 生產製程
98	静态随机存取存储器元件及其制造方法	202010428839.0	2020/5/20	發明	中國	DRAM 生產製程
99	存储器结构及其制造方法	202010466393.0	2020/5/28	發明	中國	DRAM 生產製程
100	集成电路及其制造方法	202010466375.2	2020/5/28	發明	中國	DRAM 生產製程
101	多层电容元件以及多层电容元件的设计方法	202010472946.3	2020/5/29	發明	中國	邏輯 IC
102	半导体元件的制造方法	202010498510.1	2020/6/4	發明	中國	DRAM 生產製程
103	電晶體及其製造方法	202010498516.9	2020/6/4	發明	中國	邏輯 IC
104	用于光学邻近修正的重定位方法	202010540641.1	2020/6/15	發明	中國	DRAM 生產製程
105	非揮發性記憶體結構	202010572228 .3	2020/6/22	發明	中國	DRAM 生產製程
106	半导体存储器及其部分写入方法	202010581876.5	2020/6/23	發明	中國	DRAM 生產製程
107	绝缘栅双极晶体管结构及其制造方法	202010650268.5	2020/7/8	發明	中國	邏輯 IC
108	半導體結構及其製作方法	202010679056.X	2020/7/15	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
109	半導體裝置及其製造方法	202010729805.5	2020/7/27	發明	中國	DRAM 生產製程
110	封装结构及其制作方法	202010781738.1	2020/8/6	發明	中國	DRAM 生產製程
111	线路末端结构及其形成方法	202010816535.1	2020/8/14	發明	中國	DRAM 生產製程
112	复合型存储器结构	202010965977.2	2020/9/15	發明	中國	DRAM 生產製程
113	半导体元件及其制造方法	202011008045.5	2020/9/23	發明	中國	DRAM 生產製程
114	3D NAND 闪存存储器元件	202011153992.3	2020/10/26	發明	中國	DRAM 生產製程
115	具有测试功能的存储器及其测试方法	202011272042.2	2020/11/13	發明	中國	DRAM 生產製程
116	METHOD FOR FABRICATING DRAM CELL CAPACITOR WITH OFFSET SIDEWALL CORRUGATING	202011303477.9	2020/11/19	發明	中國	DRAM 生產製程
117	非挥发性存储器元件及其制造方法	202011441535.4	2020/12/8	發明	中國	DRAM 生產製程
118	平坦化方法	202110095422.1	2021/1/25	發明	中國	DRAM 生產製程
119	测试键结构及其制造方法	202110167909.6	2021/2/7	發明	中國	DRAM 生產製程
120	半导体结构	202110167922.1	2021/2/7	發明	中國	DRAM 生產製程
121	电容集成结构、电容单元及其制造方法	202110170859.7	2021/2/8	發明	中國	邏輯 IC
122	在设计自动化平台上进行电压规则检查的计算机实施方法	202110178210.X	2021/2/9	發明	中國	DRAM 生產製程
123	闪存储存装置及其偏压方法	202110191342.6	2021/2/19	發明	中國	DRAM 生產製程
124	電容單元及其製造方法	202110198057.7	2021/2/22	發明	中國	邏輯 IC
125	eMOAT-双向可控硅整流器	202110200794.6	2021/2/23	發明	中國	DRAM 生產製程
126	eMOAT-可控硅整流器	202110253917.2	2021/3/9	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
127	記憶體元件及其製造方法	202110266366.3	2021/3/11	發明	中國	DRAM 生產製程
128	测试三维集成电路中硅穿孔的电路结构	202110371035.6	2021/4/7	發明	中國	DRAM 生產製程
129	静态随机存取存储器及其操作方法	202110376066.0	2021/4/8	發明	中國	DRAM 生產製程
130	半导体装置	202110458050.4	2021/4/27	發明	中國	邏輯 IC
131	改善芯片翘曲的方法	202110458322.0	2021/4/27	發明	中國	DRAM 生產製程
132	DRAM 電容的製造方法	202110490343.0	2021/5/6	發明	中國	DRAM 生產製程
133	半导体存储器及数据保护方法	202110544192.2	2021/5/19	發明	中國	DRAM 生產製程
134	单光子发光元件与发光装置	202110563680.8	2021/5/24	發明	中國	DRAM 生產製程
135	MEMORY PROCESSOR-BASED MULTIPROCESSING ARCHITECTURE AND OPERATION METHOD THEREOF	16/503,652	2019/7/5	發明	美國	DRAM 生產製程
136	MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/509,516	2019/7/12	發明	美國	DRAM 生產製程
137	CAPACITOR UNIT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/518,927	2019/7/22	發明	美國	邏輯 IC
138	WAFER CHUCK APPARATUS, METHOD FOR MEASURING WAFER BOW VALUE AND SEMICONDUCTOR PROCESS FLOW	16/518,998	2019/7/23	發明	美國	DRAM 生產製程
139	可執行人工智慧運算的記憶體晶片及其操作方法	16/548,792	2019/8/22	發明	美國	DRAM 生產製程
140	ERASE CONTROL CIRCUIT AND METHOD OF NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE, AND NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE	16/574,099	2019/9/18	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
141	CHANNEL ALL AROUND SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	16/575,409	2019/9/19	發明	美國	邏輯 IC
142	SHIELD GATE MOSFET AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	16/663,365	2019/10/25	發明	美國	邏輯 IC
143	晶圓圖的辨識方法與電腦可讀取記錄媒體	16/721,924	2019/12/20	發明	美國	DRAM 生產製程
144	被動元件-MCP0046-Capacitor	16741691.0	2020/1/13	發明	美國	邏輯 IC
145	半導體封裝	16/777,903	2020/1/31	發明	美國	DRAM 生產製程
146	MEMORY, MEMORY CHIP AND MEMORY DATA ACCESS METHOD	16/779,677	2020/2/3	發明	美國	DRAM 生產製程
147	IMAGE SENSOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/785,666	2020/2/10	發明	美國	邏輯 IC
148	半導體封裝	16/796,911	2020/2/20	發明	美國	DRAM 生產製程
149	MICROLENS STRCUTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREFORE	16/813,757	2020/3/10	發明	美國	邏輯 IC
150	METHOD OF MANUFACTURING PHASE-SHIFTING PHOTOMASK	16/842,776	2020/4/8	發明	美國	DRAM 生產製程
151	SOLID-STATE IMAGE SENSOR WITH PILLAR SURFACE MICROSTRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	16/845,046	2020/4/9	發明	美國	邏輯 IC
152	MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/858,746	2020/4/27	發明	美國	DRAM 生產製程
153	SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/858,717	2020/4/27	發明	美國	邏輯 IC
154	MAXRAM-SEMICONDUCTOR MEMORY AND PARTIAL WRITING METHOD THEREOF	16/868,544	2020/5/7	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
155	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/869,593	2020/5/8	發明	美國	DRAM 生產製程
156	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/877,502	2020/5/19	發明	美國	邏輯 IC
157	METHOD OF MANUFACTURING MEMORY STURCTURE	16/880,937	2020/5/21	發明	美國	DRAM 生產製程
158	INSULATED GATE FIELD EFFECT BIPOLAR TRANSISTOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/883,997	2020/5/26	發明	美國	邏輯 IC
159	IMAGE SENSING MODULE	16/898,412	2020/6/10	發明	美國	邏輯 IC
160	A Multi-layer Capacitor Device，多層電容結構與製造方法	16/905,926	2020/6/19	發明	美國	邏輯 IC
161	電晶體及其製造方法	16/916,044	2020/6/29	發明	美國	邏輯 IC
162	MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE	16/921,946	2020/7/7	發明	美國	DRAM 生產製程
163	SEMICONDUCTOR PATTERNING PROCESS	16/924,131	2020/7/8	發明	美國	DRAM 生產製程
164	INTEGRATED CIRCUIT AND METHOD OF MANUFACTURING SAME	16/925,308	2020/7/9	發明	美國	DRAM 生產製程
165	MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/926,760	2020/7/12	發明	美國	DRAM 生產製程
166	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	16/931,411	2020/7/16	發明	美國	DRAM 生產製程
167	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	16/942,731	2020/7/29	發明	美國	DRAM 生產製程
168	MEMORY STRUCTURE	16/944,162	2020/7/31	發明	美國	DRAM 生產製程
169	缺陷辨識方法以及影像分析系統	16/993,294	2020/8/14	發明	美國	DRAM 生產製程
170	絕緣閘雙極電晶體結構及其製造方法	17/000,371	2020/8/24	發明	美國	邏輯 IC
171	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND INTEGRATED CIRCUIT	17/008,642	2020/9/1	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
172	具有測試功能的記憶體及其測試方法	17/015,086	2020/9/9	發明	美國	DRAM 生產製程
173	THE NOVEL METHOD OF CONTROL AIR GAP RATIO FORMATION	17/019,328	2020/9/13	發明	美國	DRAM 生產製程
174	一種減少位元線偶合的半導體結構與其製造方法	17/024,717	2020/9/18	發明	美國	DRAM 生產製程
175	HYBRID MEMORY STRUCTURE	17/033,945	2020/9/28	發明	美國	DRAM 生產製程
176	MEMORY STRUCTURE	17/075,705	2020/10/21	發明	美國	DRAM 生產製程
177	MEMORY STRUCTURE	17/075,708	2020/10/21	發明	美國	DRAM 生產製程
178	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	17/093,585	2020/11/9	發明	美國	DRAM 生產製程
179	ANALYSIS METHOD AND ANALYSIS SYSTEM OF VOLTAGE CONTRAST DEFECT	17/092,324	2020/11/9	發明	美國	DRAM 生產製程
180	3D NAND FLASH MEMORY DEVICE	16/952,078	2020/11/19	發明	美國	DRAM 生產製程
181	MEMORY STRUCTURE	17/115,811	2020/12/9	發明	美國	DRAM 生產製程
182	METHOD OF MANUFACTURING TRENCH TRANSISTOR STRUCTURE	17/115,799	2020/12/9	發明	美國	DRAM 生產製程
183	PHASE SHIFT MASK AND MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE	17/120,278	2020/12/14	發明	美國	DRAM 生產製程
184	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	17/144,101	2021/1/7	發明	美國	DRAM 生產製程
185	MANUFACTURING METHOD OF IMAGE SENSOR	17/145,413	2021/1/11	發明	美國	邏輯 IC
186	SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	17/147,476	2021/1/13	發明	美國	DRAM 生產製程
187	PLANARIZATION METHOD	17/160,402	2021/1/28	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
188	MEMORY STRUCTURE	17/182,149	2021/2/22	發明	美國	DRAM 生產製程
189	CAPACITOR STRUCTURES FOR MEMORY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	17/202,301	2021/3/15	發明	美國	DRAM 生產製程
190	FINGERPRINT SENSING SYSTEM	17/203,725	2021/3/16	發明	美國	邏輯 IC
191	FLASH MEMORY STORAGE APPARATUS AND A BIASING METHOD THEREOF	17/204,955	2021/3/18	發明	美國	DRAM 生產製程
192	SEMICONDUCTOR MEMORY AND DATA PROTECTION METHOD	17/206,141	2021/3/19	發明	美國	DRAM 生產製程
193	DUAL-DIRECTIONAL SILICON-CONTROLLED	17/210,520	2021/3/24	發明	美國	DRAM 生產製程
194	SILICON-CONTROLLED RECTIFIER	17/218,168	2021/3/31	發明	美國	DRAM 生產製程
195	METHOD FOR MANUFACTURING METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TRANSISTOR	17/226,097	2021/4/9	發明	美國	DRAM 生產製程
196	靜態隨機存取記憶體及其操作方法	17/229,823	2021/4/13	發明	美國	DRAM 生產製程
197	SEMICONDUCTOR MEMORY WITH TEMPERATURE DEPENDENCE	17/306,918	2021/5/3	發明	美國	DRAM 生產製程
198	DRAM 電容的製造方法	17/308,072	2021/5/5	發明	美國	DRAM 生產製程
199	SEMICONDUCTOR PACKAGE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	17/319,119	2021/5/13	發明	美國	DRAM 生產製程
200	SUB-SENSE AMPLIFIER AND SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE	17/342,565	2021/6/9	發明	美國	DRAM 生產製程
201	MULTI-LAYER CAPACITOR UNIT AND MANUFACTURING PROCESS THEREOF	17352255.0	2021/6/19	發明	美國	邏輯 IC
202	具有記憶體內運算架構的記憶體及其操作方法	108119618.0	2019/6/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
203	膜厚量測系統及膜厚量測方法	108125590.0	2019/7/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
204	通道全環繞半導體裝置及其製造方法	108125557.0	2019/7/19	發明	臺灣	邏輯 IC
205	記憶體結構及其製造方法	108127748.0	2019/8/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
206	固定環	108128172.0	2019/8/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
207	半導體結構及其製造方法	108146564.0	2019/12/19	發明	臺灣	邏輯 IC
208	半導體封裝	109100303.0	2020/1/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
209	影像感測器結構及其製造方法	109101139.0	2020/1/14	發明	臺灣	邏輯 IC
210	電容結構以及其製作方法	109102061.0	2020/1/21	發明	臺灣	邏輯 IC
211	非揮發性記憶體元件及其製造方法	109105454.0	2020/2/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
212	半導體元件及其製造方法	109108160.0	2020/3/12	發明	臺灣	邏輯 IC
213	半導體裝置	109108746.0	2020/3/17	發明	臺灣	邏輯 IC
214	非揮發性記憶體元件	109111126.0	2020/4/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
215	氣動元件用的供氣洩漏偵測系統	109111257.0	2020/4/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
216	氣體噴灑裝置、半導體基板處理設備及其操作方法	109111447.0	2020/4/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
217	半導體結構及其製造方法	109112408.0	2020/4/13	發明	臺灣	邏輯 IC
218	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	109113251.0	2020/4/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
219	半導體元件及其製造方法	109114255.0	2020/4/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
220	半導體圖案化製程	109114871.0	2020/5/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
221	半導體結構及其製造方法	109114881.0	2020/5/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
222	圖案化方法	109114883.0	2020/5/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
223	記憶體結構及其製造方法	109115448.0	2020/5/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
224	積體電路及其製造方法	109115449.0	2020/5/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
225	非揮發性記憶體結構	109116212.0	2020/5/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
226	光罩的形成方法及離子植入罩幕的製造方法	109116213.0	2020/5/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
227	電晶體及其製造方法	109116418.0	2020/5/18	發明	臺灣	邏輯 IC
228	半導體製程用游標尺及使用其進行的微影製程檢測方法	109116487.0	2020/5/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
229	半導體元件及其製造方法	109116476.0	2020/5/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
230	用於光學鄰近修正的重定位方法	109117643.0	2020/5/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
231	半導體元件的製造方法	109119490.0	2020/6/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
232	半導體記憶體及其部分寫入方法	109119486.0	2020/6/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
233	晶圓處理方法及晶圓固持裝置	109120750.0	2020/6/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
234	缺陷辨識方法以及影像分析系統	109122218.0	2020/7/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
235	非揮發性記憶體結構	109122202.0	2020/7/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
236	半導體結構及其製作方法	109122239.0	2020/7/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
237	影像感測裝置	109123713.0	2020/7/14	發明	臺灣	邏輯 IC
238	廢磷酸液回收系統與方法	109124412.0	2020/7/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
239	電晶體結構及其製造方法	109124671.0	2020/7/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
240	封裝結構及其製作方法	109124926.0	2020/7/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
241	半導體製程控制系統及半導體製程控制方法	109125394.0	2020/7/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
242	THE NOVEL METHOD OF CONTROL AIR GAP RATIO FORMATION	109126234.0	2020/8/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
243	電壓對比缺陷的分析方法及分析系統	109126588.0	2020/8/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
244	A HV DEVICE WITH VERTICALLY EXTENDED DRIFT REGION	109127948.0	2020/8/17	發明	臺灣	邏輯 IC

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
245	A DEVICE CORRELATED ION IMPLANTATION CONTROL METHOD (MACHINE LEARNING)	109128635.0	2020/8/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
246	一種減少位元線偶合的半導體結構與其製造方法	109128793.0	2020/8/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
247	記憶體的讀取方法	109129436.0	2020/8/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
248	複合型記憶體結構	109130199.0	2020/9/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
249	影像感測器	109130305.0	2020/9/4	發明	臺灣	邏輯 IC
250	BL LINE END FORMATION METHOD	109131160.0	2020/9/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
251	減少淺溝渠隔離結構邊緣凹陷的方法	109132833.0	2020/9/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
252	鉑的圖案化方法	109132823.0	2020/9/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
253	晶圓盒搬運夾具	109134042.0	2020/9/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
254	非揮發性記憶體結構及其製造方法	109134000.0	2020/9/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
255	試片製備方法及試片製備系統	109134522.0	2020/10/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
256	3D NAND 快閃記憶體元件	109134727.0	2020/10/7	發明	臺灣	DRAM 生產製程
257	擺盪曲線的產生方法	109135504.0	2020/10/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
258	照明源最佳化的方法	109136601.0	2020/10/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
259	矽穿孔結構及其製作方法	109137019.0	2020/10/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
260	具有測試功能的記憶體及其測試方法	109137677.0	2020/10/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
261	半導體裝置及其製造方法	109138932.0	2020/11/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
262	鉑的圖案化方法	109138933.0	2020/11/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
263	記憶體的電容結構與其製作方法	109139096.0	2020/11/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
264	密合度偵測系統及密合度偵測方法	109139483.0	2020/11/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
265	半導體加工的方法及製具	109140047.0	2020/11/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
266	相移遮罩及半導體元件的製作方法	109140049.0	2020/11/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
267	非揮發性記憶體元件及其製造方法	109140994.0	2020/11/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
268	導線結構的製造方法	109141703.0	2020/11/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
269	半導體裝置及其製造方法	109143094.0	2020/12/7	發明	臺灣	DRAM 生產製程
270	OPTIMIZATION NS300 AS2 NOZZLE WATERPROOF COVER	109143169.0	2020/12/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
271	資料儲存裝置與資料儲存裝置的控制方法	109144169.0	2020/12/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
272	金屬-絕緣體-金屬電容結構及其製作方法	110100003.0	2021/1/4	發明	臺灣	邏輯 IC
273	半導體裝置及其製造方法	110100074.0	2021/1/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
274	影像感測器及其製造方法	110100075.0	2021/1/4	發明	臺灣	邏輯 IC
275	測試鍵結構及其製造方法	110100031.0	2021/1/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
276	金屬氧化物半導體電晶體的製造方法	110100060.0	2021/1/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
277	平坦化方法	110100051.0	2021/1/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
278	管理方法及生產系統	110100413.0	2021/1/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
279	半導體結構	110100849.0	2021/1/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
280	半導體結構	110100849.0	2021/1/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
281	半導體元件的主動區域的製作方法	110101278.0	2021/1/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
282	對位結構及其形成方法	110101701.0	2021/1/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
283	電容集成結構、電容單元及其製造方法	110102113.0	2021/1/20	發明	臺灣	邏輯 IC
284	用以定義閘介電層的光罩的布局設計方法	110102427.0	2021/1/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
285	電容單元及其製造方法	110103641.0	2021/2/1	發明	臺灣	邏輯 IC
286	在電子設計自動化平台上進行電壓規則檢查的電腦實施方法	110103821.0	2021/2/2	發明	臺灣	DRAM 生產製程
287	非揮發性記憶體結構及其製造方法	110103817.0	2021/2/2	發明	臺灣	DRAM 生產製程
288	記憶體元件及其製造方法	110103988.0	2021/2/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
289	修整半導體結構的方法	110104037.0	2021/2/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
290	快閃記憶體儲存裝置及其偏壓方法	110104200.0	2021/2/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
291	指紋感測系統	110104177.0	2021/2/4	發明	臺灣	邏輯 IC
292	警示方法及警示系統	110104343.0	2021/2/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
293	測試半導體圖案的方法	110106660.0	2021/2/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
294	背照式影像感測器及其製造方法	110107227.0	2021/3/2	發明	臺灣	邏輯 IC
295	靜態隨機存取記憶體及其操作方法	110107514.0	2021/3/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
296	半導體裝置及其製造方法	110107873.0	2021/3/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
297	液體供應系統及液量輔助判斷方法	110109268.0	2021/3/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
298	半導體圖案的生成方法	110109544.0	2021/3/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
299	半導體封裝及其製造方法	110109889.0	2021/3/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
300	半導體裝置及其製造方法	110109891.0	2021/3/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
301	閘介電層的製造方法	110110413.0	2021/3/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
302	測試三維積體電路中矽穿孔的電路結構	110110430.0	2021/3/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
303	eMOAT-雙向矽控整流器	110110505.0	2021/3/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
304	背照式影像感測器及其製造方法	110110921.0	2021/3/25	發明	臺灣	邏輯 IC
305	半導體裝置	110110894.0	2021/3/25	發明	臺灣	邏輯 IC
306	半導體元件及其製造方法	110111199.0	2021/3/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
307	半導體裝置的缺陷分析方法與電子裝置	110111694.0	2021/3/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
308	具有保全功能的半導體裝置及其保全方法	110111434.0	2021/3/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
309	矽控整流器	110111750.0	2021/3/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
310	深溝渠式電容器及其製造方法	110112684.0	2021/4/8	發明	臺灣	邏輯 IC
311	改善晶圓翹曲的方法	110113902.0	2021/4/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
312	非揮發性記憶體裝置及其程式化驗證電壓的設定方法	110114284.0	2021/4/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
313	沉積製程控制方法	110115545.0	2021/4/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
314	半導體記憶體及資料保護方法	110115948.0	2021/5/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
315	單光子發光元件與發光裝置	110116391.0	2021/5/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
316	電晶體結構及其製造方法	110116678.0	2021/5/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
317	感測電路以及測試裝置	110117683.0	2021/5/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
318	非揮發性記憶體結構	110117737.0	2021/5/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
319	記憶體裝置	110119697.0	2021/5/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
320	次級感測放大器與半導體記憶裝置	110120949.0	2021/6/9	發明	臺灣	DRAM 生產製程
321	電晶體結構與記憶體結構	110121650.0	2021/6/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
322	旋鈕式化學晶舟	110121692.0	2021/6/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
323	晶圓堆疊結構及其製造方法	110122035.0	2021/6/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
324	半導體結構以及其形成方法	110122309.0	2021/6/18	發明	臺灣	邏輯 IC
325	具有溫度依存性的半導體記憶體	110122754.0	2021/6/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
326	晶圓搜尋方法及裝置	110122947.0	2021/6/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
327	半導體電容結構	110122953.0	2021/6/23	發明	臺灣	邏輯 IC
328	半導體封裝	110123375.0	2021/6/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
329	晶圓清洗刷	110124078.0	2021/6/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
330	人工知能動作を実行できるメモリチップおよびその方法	2019-171109	2019/9/20	發明	日本	DRAM 生產製程
331	回路構造	2019-235821	2019/12/26	發明	日本	邏輯 IC
332	全周チャンネル型半導体装置およびその製造方法	2020-002688	2020/1/10	發明	日本	邏輯 IC
333	IV CONVERTOR WITH WIDE RANGE CURRENT MIRROR AND USAGE ON FLASH MEMORY	2020-203224	2020/12/8	發明	日本	DRAM 生產製程
334	半導體封裝	10-2020-0026437	2020/3/3	發明	韓國	DRAM 生產製程
335	半導體封裝	10-2020-0037749	2020/3/27	發明	韓國	DRAM 生產製程

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)商標權

國別	取得	申請中	合計
臺灣	3	—	3
歐盟	1	—	1
新加坡	1	—	1
美國	1	—	1
中國	3	—	3
日本	1	—	1
合計	10	—	10

資料來源：該公司及其子公司提供

截至送件日止已取得之商標權列示如下：

A.已取得之商標權

項次	專用期限	證書號碼	商標圖樣	申請國家
1	2019/07/16-2029/07/15	7997927	PSMC	臺灣
2	2019/09/16-2029/09/15	2011795		
3	2019/09/16-2029/09/15	2011970		
4	2020/07/14-2030/07/13	18182117		歐盟
5	2020/01/17-2030/01/16	40202001283Y		新加坡
6	2021/03/09-2031/03/08	6286009		美國
7	2021/04/07-2031/04/06	41164671		中國
8	2021/01/28-2031/01/27	41164670		
9	2021/01/28-2031/01/27	41164669		
10	2021/06/21-2031/06/21	6404976		日本

資料來源：該公司及其子公司提供

7.以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃、預計生產時程及成本、市場定位、需求及未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施

(1)產品生產開發技術之層次、來源

該公司及其子公司長期耕耘於半導體晶圓代工服務，透過 Open Foundry 營運模式，從晶片設計到製造服務，可根據不同的屬性和需求，提供客戶所需之代工服務，藉此與客戶建立緊密及彈性的合作機制。藉由活化成熟生產技術並善用製程優勢，該公司及其子公司得以提供大規模高性價比之產品技術。所提供的製程技術及製造解決方案，包括邏輯暨特殊應用以及記憶體兩大群組產品之代工技術：

A.邏輯暨特殊應用產品之代工技術

摩爾定律在 28 奈米節點之後，提升幅度減緩顯示先進邏輯製程不是市場唯一方向，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊應用製程(應用於顯示驅動 IC、分離式元件、電源管理晶片、CMOS 影像感測器、嵌入式非揮發記憶體之製造)及多元代工合作模式，以有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是該公司及其子公司的競爭策略，28 奈米以上成熟製程市場依然有相當大的規模，包括 IoT、工業、汽車電子等應用。隨著智慧型手機產品的普遍及人工智慧相關產品的推出，促使物聯網(IoT)產業鏈逐漸成形，更帶動上下游相關元件需求。在消費性終端產品「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，對專業晶圓代工廠而言，能提供客戶客製化製程開發更形重要。

(A)高壓製程(High Voltage)

應用於手機、筆記型電腦、平板、TV 及電腦螢幕等電子產品的面板顯示驅動 IC。由於新冠肺炎疫情的關係居家上班與遠距教學成為新常態，筆記型電腦/平板電腦需求增加，加上 4K/8K 電視的滲透率上升，造成驅動 IC 需求增加、缺貨、價格上漲。該公司及其子公司將 8 吋大面板驅動 IC 高壓製程移植到 12 吋廠生產，為臺灣地區主要在 12 吋晶圓廠生產大面板驅動 IC 之晶圓代工廠，晶粒生產成本可大幅降低 30%。

(B)分離式元件(Discrete)

應用在各類產品如手機/平板電池保護、PC/NB 主機板、工具機、USB、訊號開關、馬達驅動及 LED lighting 等。5G 商轉全球正式邁入 5G 世代，相較於 4G，5G 基站的 MOSFET 需求成長大於 4 倍，該公司及其子公司除 8 吋擴廠外、亦開始著手 12 吋廠開始分離式元件平台，目前亦為臺灣主要在 12 吋晶圓廠建立此產品線之晶圓代工廠。

(C)CMOS 影像感測器

目前以 CIS 製程為客戶生產高解析度之影像感測晶片，並自行開發後段彩色濾光膜(color filter)與微鏡頭(micro lens)製程，以提供客戶更全面的 CIS 代工服務。智慧型手機鏡頭微 CMOS 影像感測器最大需求來源，手機使用鏡頭逐年增加目前已經來到平均單隻手機有四顆鏡頭；加上各國安防監控影像感測器需求亦持續上升，特別是在大陸地區。該公司及其子公司與國際大廠合作，在手機輔助鏡頭、安全監控器及車用行車紀錄器、倒車輔助等應用的晶片代工市占率遠遠高於其他晶圓代工競爭者。

(D)電源管理製程(Power Management)

應用在各類 Power IC，如手機 PMIC、Charger、LDO、Boost converter、LED lighting、AD/DC、HV motor driver。2019~2021 年各國開始全力支援 5G 商轉，5G 技術以高速傳輸、低延遲、大量連網為特色。除了 5G 基礎建設帶動的商機，也將引發終端設備新一波的升級換機需求。相對 4G 手機，5G 手機 PMIC 使用顆數是 4~5 倍，晶片用量則是 2.5~3 倍。該公司及其子公司與世界大廠合作，率先在 12 吋生產手機用 PMIC 晶片，並與客戶共同開發下一代電源管理製程。

(E)嵌入式非揮發記憶體(Embedded NVM)

應用消費性電子、工程及車用電子等。因人工智慧技術及效能的提升，物聯網及 5G 行動通訊建設臻於完善，興起許多新型態終端產品，使晶片設計複雜度不斷提昇；除追求晶片功能整合及低功耗外，還需考慮生產效能或是進一步要求半導體製程技術微縮。目前除了提供 110nm~55nm 製程平台且進入量產之外，亦積極開發 40nm 製程平台，提供客戶更低功耗、更小單位元件面積之產品。

B.記憶體產品之代工技術

(A)動態隨機存取記憶體(DRAM)

該公司及其子公司在 DRAM 代工領域深耕多年，為目前業界少數可提供 12 吋先進 DRAM 製程的代工廠商。目前除了 45nm 等成熟製程外，更積極協助客戶導入 38nm 及 25nm 製程，以滿足產品多樣化的需求。

(B)快閃記憶體(NAND/NOR Flash)

該公司及其子公司多年累積快閃記憶體產品技術成果，在 NAND Flash 方面目前已提供 40nm 及 28nm 代工製程與產品設計服務。而 24nm 製程也已進入試產階段。

NOR Flash 方面，目前已提供客戶 90nm 製程 NOR Flash 代工，48nm 製程已於 2020 年進入試產階段，並於 2021 年進入量產將更具成本優勢。

(2)技術之確保與提升

該公司及其子公司係以自行研發的製程技術、營業秘密、相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，為保護公司研發成果及技術之智慧財產權，各階段之研發文件及資料皆上傳至有授權管制之文件管理系統中，並且將新產品相關製程之研發成果申請專利權保護。該公司及其子公司除透過內部課程自行培育研發人才外，亦透過與共同開發夥伴密切合作、與工研院及學校合作，確保產品技術持續提升。

(3)現在主要產品之競爭優勢、生命週期及持續發展性

A.主要產品之競爭優勢

該公司及其子公司之代工技術分為邏輯暨特殊應用以及記憶體兩大群組產品，以下就主要產品分析其競爭優勢：

(A)邏輯暨特殊應用產品晶圓代工業務

一般 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，該公司及其子公司能提供低成本的 12 吋鋁製程平台，相較同樣產品製程技術的 8 吋鋁製程，該公司及其子公司 12 吋鋁製程所產出之最後產品晶片成本可降低 30%以上，大幅提升客戶產品競爭力。

該公司及其子公司著重在 IoT、工業、汽車電子等特殊應用產品市場，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊製程及多元代工合作模式，有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是該公司及其子公司的競爭策略。

a.高壓製程(High Voltage)

該公司及其子公司提供低成本的 12 吋鋁製程 150nm~80nm 高壓製程平台用於大小面板驅動 IC 產品，有別於一般 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，相較同業產品製程技術的 8 吋鋁製程，該公司及其子

公司晶粒成本可大幅降低 30%以上。此外，小面板驅動 IC 需要內建靜態隨機存取記憶體(SRAM)，記憶體之單位元件大小會影響到產品晶片大小與成本，該公司及其子公司提供之 55nm~40nm 高壓製程平台之 SRAM 記憶體之單位元件與競爭對手對比相當的競爭力。

b.分離式元件(Discrete)

該公司及其子公司著手於 12 吋廠開發分離式元件平台，亦為目前臺灣主要在 12 吋晶圓廠建立此產品線之晶圓代工廠，相較同樣產品製程技術的 6 吋及 8 吋製程，該公司及其子公司所產出之最後產品晶片成本可降低 30%以上。

c.CMOS 影像感測器

該公司及其子公司 CIS 影像感測器平台，提供低成本、低耗電、高穩定性及整合性高等優勢，平均良率高於 97%。

d.電源管理製程(Power Management)

該公司及其子公司憑藉技術優勢，積極開發拓展各節點類比電源管理晶片平台以符合市場與客戶需求。數位電路面積降為競爭對手 1/4，類比電路面積降為競爭對手 9/10。

e.嵌入式非揮發記憶體製程(Embedded NVM)

該公司及其子公司 eFlash 採用新一代 Flash 架構，需要額外光罩層數與最大電壓，均優於競爭對手。

(B)記憶體晶圓代工業務

a.動態隨機存取記憶體(DRAM)

該公司及其子公司 DRAM 記憶體代工產品線有別於其他 IDM 廠，為目前全球主要能提供客製化DRAM產品及完整優化製程服務的公司，為記憶體 IC 設計公司缺一不可的重要合作夥伴。

b.快閃記憶體(NAND/NOR Flash)

該公司及其子公司多年累積快閃記憶體產品技術成果，在 NAND Flash 方面，提供 40nm 及 28nm 代工製程與產品設計服務。鎖定行動通訊應用裝置、消費性電子產品、汽車聯網、及工業應用市場，提供低功率節能及高可靠度的 NAND Flash 產品。在 NOR Flash 方面，該公司及其子公司 12 吋晶圓廠機台配置用於生產 NOR Flash 及具成本優勢。

B.生命週期及持續發展性

半導體晶片終端應用產品非常廣泛，惟隨著各項電子終端產品要求「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，終端產品生命週期縮短也影響著半導體製造晶圓生命週期持續縮短，半導體製程技術密集度也越來越高，該公司及其子公司除強

化自身產品技術線外，持續往下一代先進製程進行開發，同時也加強既有之成熟製程能力。受惠於車用、5G、人工智慧物聯網(AIoT)等終端應用快速興起，晶圓代工需求強勁，對全球半導體產業造成結構性的改變，目前市場對成熟製程的晶片需求出現大爆發的情況，未來供不應求將更嚴重。

(4)新產品之研究開發計畫、預計生產時程及成本

該公司及其子公司為因應 5G 基地台、車用元件及物聯網市場，制定多項研發計畫，透過過往經驗與生產製造能力，預計研發多項邏輯暨特殊應用產品代工及記憶產品代工技術，並以該公司及其子公司原有核心技術為基礎，逐步推進先進製程以發展至各種產品之應用技術。該合併公司每年約投入營業收入之 7%作為研究開發經費。茲將目前研發項目及預訂時程列示如下：

研發項目	說明
55nm L55 新應用和新客戶導入	預定 2022 量產
40nm HV40 高壓製程	預定 2021 完成開發
40nm L40 邏輯製程客戶導入	預定 2022 量產
40nm eFlash (IMC40)製程	預定 2023 完成開發
38nm DRAM 55nm Logic wafer stacking 製程	預定 2021 完成開發
WOW Logic and DRAM stacking (3D Interchip)製程	預定 2022 完成開發
90nm CIS 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_BSI 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_Global Shutter 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_Bio-Chop 製程	預定 2022 完成開發
21nm DRAM 8GD4 (186AD)製程	預定 2021 完成開發
25nm DRAM 4G DDR3 RDL(KGD)製程	預定 2021 完成開發
38nm DRAM embedded capacito 製程	預定 2022 完成開發
24nm NAND Flash (DK24)製程	預定 2022 完成開發
80nm BCD 1.2V(1.8V)/5V 製程	G1:5V GOX 2022 開發完成 G2:1.8V GOX 2023 開發完成
90nm BCD(SG90)	預定 2021 完成開發
130nm BCD 1.5V/5V/80V	預定 2022 完成開發
GaN on Si Power Device	預定 2023 完成開發
150nm Micro-bolometer IR Image Sensor	預定 2022 完成開發
110nm MCU	預定 2021 完成開發
110nm Data storage	預定 2021 完成開發
Discrete, MLSC LD and HD capacitor	預定 2021 完成開發

資料來源：該公司及其子公司提供

(5)新產品之市場定位、需求及未來營收效益預測達成可能性

隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦。該公司及其子公司同時擁有 8 吋及 12 吋鋁製程的晶圓代工方案，成為該公司及其子公司在成熟邏輯代工業務有別於其他市場競爭者的成本規模優勢。而利基型記憶體透過與高效能且先進的邏輯晶片結合之獨特封裝技術概念，亦為市場提供一新穎且產生更大效益的代工合作方案。

半導體代工市場需求量前景樂觀，且該公司及其子公司持續擴建新廠增加產能，預計未來全球代工市場之營收規模及市占率將持續提升，未來業績成長尚屬可期。

(6)研究發展之內部控制暨保全措施

該公司及其子公司已於內部控制制度中之研發循環訂有相關作業予以規範，包括基礎研究、產品設計、技術研發、產品試作及測試、智慧財產權之取得、維護及運用等作業程序及相關控制重點，以利研究發展作業有效之執行，並確保研發作業管理之落實。另於研究發展之保全措施方面，該公司及其子公司各階段之研發文件及資料皆上傳至有授權管制之文件管理系統中，按不同性質屬性建檔標示管理，且技術文件依機密程度分類建檔，應經核准後，方能取得機密文件，並設有簽收簿。研發成果移轉階段中，新產品相關製程指導規範皆由研發文件保管權責單位妥善保管。該公司及其子公司禁用私人儲存裝置、私人設備禁止拍照錄影、列印影印傳真皆有控管、到職同仁簽有保密協議。另外，該公司及其子公司設有智權室，鼓勵同仁將研發成果提出專利之申請，以保障公司研發成果之智慧財產權。

8.以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股五%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三年度及申請年度內股權移轉變化暨實際投入經營之時間與情形等，以評估該等人員未來若未能繼續參與經營對公司之營運風險，及其因應之措施

(1)該公司及其子公司係以科技事業申請股票上市，設有審計委員會取代監察人職務，另該公司及其子公司並無以專利權或專門技術出資之股東，持股 5%以上之股東為力晶科技股份有限公司，茲將該公司及其子公司董事、持股 5%以上之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷(工作經理、教育背景及職位年資)、持股比例、實際投入經營之時間與情形列示如下：

110 年 7 年 29 日；股數：股

職稱	姓名	學歷	經歷	持股股數	持股比例	產業年資	於該公司服務年資
董事長暨執行長	黃崇仁	美國紐約大學	西奈山醫學院醫學博士 力晶集團董事長 力晶科技(股)公司技術暨策略總監	115,635,061	3.40	26	3

職稱	姓名	學歷	經歷	持股股數	持股比例	產業年資	於該公司服務年資
董事 副執行長暨總經理	謝再居	美國俄亥俄州辛辛那堤電機博士	美國德州大學(Arlington)電機系副教授兼研究中心主任 力晶科技(股)公司副執行長暨先進技術總監	1,687,029	0.05	36	3
董事	仁典投資(股)公司	-	-	16,451,676	0.48	-	-
	代表人：邵章榮	國立臺灣大學國際企業碩士	力晶科技(股)公司總經理特別助理 力晶科技(股)公司副總經理	89,000	0.00	24	3
董事	力晶科技(股)公司	-	-	835,486,370	24.54	-	-
	代表人：徐清祥	美國伊利諾依大學電機系博士	國立清華大學電子研究所所長 美國紐約州 IBM T. J.華生研究中心研究員 力旺電子股份有限公司董事長 漢芝電子(股)公司董事長 PUFsecurity USA Corporation 董事長 熵碼科技(股)公司法人董事長代表人暨總經理 安瀚科技(股)公司法人董事代表 宏碁(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 閎康科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 財團法人國家實驗研究院董事	205,032	0.01	註	註
獨立董事	吳重雨	國立交通大學電子工程博士	國立交通大學校長 晶焱科技股份有限公司獨立董事	-	-	註	註
獨立董事	張嘉臨	美國普林斯頓電機工程博士 美國賓州大學華頓商學院MBA	美國摩托羅拉公司半導體工程師 美商高盛投資銀行全球合夥人 宏達國際電子(股)公司總經理及財務長	-	-	註	註
獨立董事	林憲銘	國立交通大學電子計算機與控制工程學士	宏碁電腦(股)公司總經理	-	-	註	註
獨立董事	林本堅	美國俄亥俄州立大學電機工程學系博士 國立臺灣大學電機工程學系學士	美國國際商用機器公司研究員、研發經理、部經理、幕僚 臺灣積體電路製造股份有限公司資深處長、傑出科技院士/副總經理	-	-	註	註

職稱	姓名	學歷	經歷	持股股數	持股比例	產業年資	於該公司服務年資
			國立清華大學特聘研究講座教授 國立交通大學特聘研究講座教授 國立臺灣大學特聘研究講座教授 國立清華大學台積電聯合研發中心主任 美國領創公司總經理				
獨立董事	葉疏	美國加州大學洛杉磯分校會計學博士	中華電信股份有限公司財務長暨執行副總經理 中華電信股份有限公司獨立董事 愛普科技股份有限公司獨立董事兼審計及薪酬委員 國立臺灣大學會計系教授 捷敏股份有限公司獨立董事兼審計及薪酬委員 龍巖股份有限公司獨立董事兼審計及薪酬委員	-	-	註	註
技術長	張守仁	國立臺灣大學電機博士	臺灣積體電路製造(股)公司副處長 力晶科技(股)公司協理	1,196,211	0.04	23	3

資料來源：該公司及其子公司提供
註：非屬該公司及其子公司員工故無年資統計

(2)參與經營決策之董事、監察人、持股五%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人最近三年度及申請年度內股權移轉變化情形：

該公司及其子公司 107~109 年及 110 年截至 7 月 29 日止，並無以專利權或專門技術出資之股東；另該公司及其子公司參與決策之董事、持股五%以上股東及掌握生產技術與技術開發經理人等 107~109 年及 110 年截至 7 月 29 日止股權移轉變化情形，列示如下：

單位：股

職稱	姓名	106.12.31 持股數	107 年度		107.12.31 持股數	108 年度		108.12.31 持股數	109 年度		109.12.31 持股數	110 年上半年度		110.7.29 持股數
			現增或員工認股	一般交易		現增或員工認股	一般交易		現增或員工認股	一般交易		現增或員工認股	一般交易	
董事長暨執行長	黃崇仁	-	-	-	-	4,212,306	-	4,212,306	-	101,436,485	105,648,791	9,986,270	-	115,635,061
董事/副執行長暨總經理	謝再居	-	-	-	-	613,480	-	613,480	-	625,793	1,239,273	597,756	(150,000)	1,687,029
董事	仁典投資(股)公司	-	-	-	-	- (註 3)	-	1,100,000	-	14,035,619	15,135,619	1,316,057	-	16,451,676
	代表人：邵章榮	-	-	-	-	411,000	(171,000)	240,000	-	(240,000)	-	230,000	(141,000)	89,000
董事	力晶科技(股)公司	306,364,239	52,303,204 (註 1)	-	358,667,443	-	2,346,529,126	2,705,196,569	-	(1,879,504,929) (註 2)	825,691,640	71,794,730	(62,000,000)	835,486,370
	代表人：徐清祥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (註 4)	16,401	-	205,032
獨立董事	吳重雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	張嘉臨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林憲銘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林本堅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	葉疏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
技術長	張守仁	-	-	-	-	498,301	-	498,301	-	426,498	924,799	280,412	(9,000)	1,196,211

註 1：該公司 106 年度盈餘轉增資發行新股計 52,303,204 股。
註 2：力晶科技(股)公司於 109 年度之減少股數 1,879,504,929 股，包含 7,101,000 股為該公司申請登錄興櫃，依相關法令提撥予券商及投資人保護中心等之股數。
註 3：仁典投資(股)公司係於 108 年 11 月 13 日就任，故僅揭露 108 年 11 月 13 日至 108 年 12 月 31 日之持股異動。
註 4：係於 110 年 6 月 9 日經力晶科技(股)公司改派為代表人，故僅揭露 110 年 6 月 9 日至 110 年 6 月 30 日之持股異動。

該公司及其子公司參與經營決策之董事及掌握生產技術與技術開發經理人等之股權增加行為，大多為參與現金增資所產生；而股權移轉行為，除母公司力晶科技(股)公司於 109 年度以該公司股票抵充應退還之減資股款配發予原股東案以及配合登錄興櫃提撥股票公推薦券商認購，以至於發生較為重大之股權移轉外，其餘股權移轉行為係基於個人理財所需，並未發現重大異常情形之股權移轉或轉讓之情事。

(3)評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

該公司及其子公司董事具備業務發展所需之產業或財務經驗，其主要透過董事會運作對該公司及其子公司經營策略及方向提供適當建議，並無單一董事或集團控制該公司及其子公司經營或日常運作。另該公司及其子公司長久以來累積半導體製造之相關技術經驗，其所擁有之技術並非由單一人所能完全掌握，加上該公司及其子公司已建立並落實研發管理制度及相關作業辦法，以及研發成果之保護，且研發人員任職時皆有簽訂保密同意書，該公司及其子公司亦十分重視研發人才的培訓，規劃多元的專業在職訓練，也提供完善的福利制度及獎酬辦法，以提升對公司的向心力及奠定穩固研發團隊之根基，故上述董事及員工離職時應不致對該公司及其子公司產生重大影響。

(三)人力資源之營運風險

1.員工總人數、離職人數、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資變動情形

單位：人；年；歲；%

人數＼年度		107 年度	108 年度	109 年度	110 年度截至 6 月底止
期初人員		6,599	6,931	6,878	7,174
新進人員		919	545	964	395
離職人員		563	534	644	326
資遣人員		6	53	9	5
退休人員		18	11	15	8
期末人數	直接人工	1,878	1,850	1,898	1,926
	間接人工	5,053	5,028	5,276	5,304
	合計	6,931	6,878	7,174	7,230
平均年資		8.98	9.62	9.88	10.10
平均年齡		36.72	37.77	38.07	38.53

資料來源：該公司及其子公司提供

2.經理人、生產線員工及一般職員離職率之變化情形

單位：人；%

年度 人數	107 年度			108 年度			109 年度			110 年度截至 6 月底止		
	期末人數	離職人數	離職率(%)	期末人數	離職人數	離職率(%)	期末人數	離職人數	離職率(%)	期末人數	離職人數	離職率(%)
經理人	27	-	-	25	3	10.71	26	2	7.14	26	2	7.14
生產線員工	1,878	229	10.87	1,850	215	10.41	1,898	272	12.53	1,926	129	6.28
一般職員	5,026	358	6.65	5,003	380	7.06	5,250	394	6.98	5,278	208	3.79
合計	6,931	587	7.81	6,878	598	8.00	7,174	668	8.52	7,230	339	4.48

資料來源：該公司及其子公司提供

註：離職率=離職人數(含資遣及退休) / (期末人數+離職人數(含資遣及退休))

3.員工人數及離職率變化情形之說明

該公司及其子公司最近三年度及截至 110 年 6 月底之員工人數分別為 6,931 人、6,878 人、7,174 人及 7,230 人，其人數變化主要係依該公司及其子公司整體之營業規模逐漸擴大而整體呈現人數增加趨勢。而員工平均年齡為 36.72 歲至 38.53 歲，顯示該公司及其子公司員工主要為青壯年人口，平均年資為 8.98 年至 10.10 年，離職員工主要以生產線作業人員及一般職員為主，惟整體人數及變動尚屬正常情形，故對該公司及其子公司營運應無重大風險。

該公司及其子公司最近三年度及截至 110 年 6 月底止之總離職人數分別為 587 人、598 人、668 人及 339 人，離職率分別為 7.81%、8.00%、8.52%及 4.48%，主要係生產線員工及一般職員，其員工離職原因主係因地域環境因素、個人生涯規劃、家庭環境及工作輪班因素而離職，惟該公司及其子公司皆已依其職責招募遞補適任員工，故對營運並無重大影響。此外，最近三年度及截至 110 年 6 月底止該公司及其子公司經理人離職人數分別為 0 人、3 人、2 人及 2 人，離職率甚低，離職原因主係因生涯規劃或退休，經理人於離職時已完成工作資料交接，且該公司及其子公司於短期內由內部或外部尋找具相關工作經驗之經理人接替其職位，故經理人之離職情形並未影響營運。

4.員工學歷分析

單位：人；%

年度 項目	107 年度		108 年度		109 年度		110 年度截至 6 月底止	
	人數	比例(%)	人數	比例(%)	人數	比例(%)	人數	比例(%)
博士	42	0.61	45	0.65	49	0.68	51	0.71
碩士	2,079	30.00	2,098	30.50	2,279	31.77	2,305	31.87
大學(專)	3,767	54.34	3,703	53.85	3,806	53.05	3,839	53.10
高中(職)以下	1,043	15.05	1,032	15.00	1,040	14.50	1,035	14.32
合計	6,931	100	6,878	100.00	7,174	100.00	7,230	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司之員工學歷狀況自最近三年度及截至 110 年 6 月底，大學

(專)以上學歷之員工占全體員工比例分別為 84.95%、85.00%、85.50%及 85.68%，大學(專)以上學歷之員工分佈任職各部門，負責銷售、採購、財務及研發等各業務，而高中(職)以下學歷之員工占該公司及其子公司員工比例分別為 15.05%、15.00%、14.50%及 14.32%，主係以生產部門之作業人員為主，負責相關機械操作等作業。隨著該公司及其子公司業績成長，生產規模及產能增加，該公司及其子公司因應不同工作性質之需求，持續招募各種學歷員工，並有效利用各種學歷員工之專業與技能，有助於強化企業管理，且高階幹部與研發人員以大學(專)以上學歷為主，故整體人員素質尚屬良好，應有助於增強該公司及其子公司經營實力與競爭力。

(四)各主要產品之成本分析

1.最近期及最近三個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素之比率變化對發行公司營運之風險

單位：新臺幣仟元；%

產品名稱	類別	107 年度		108 年度		109 年度		110 年第一季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
記憶體	原物料	2,169,838	12.57	2,221,035	12.86	1,671,810	10.21	351,743	10.26
	直接人工	614,930	3.56	550,596	3.19	478,853	2.92	111,962	3.27
	製造費用	14,472,000	83.87	14,498,123	83.95	14,223,810	86.87	2,964,563	86.47
	合計	17,256,768	100.00	17,269,754	100.00	16,374,473	100.00	3,428,268	100.00
邏輯	原物料	2,667,274	17.96	2,431,125	19.76	2,710,367	14.78	707,676	14.46
	直接人工	919,634	6.19	761,728	6.19	991,074	5.41	284,695	5.82
	製造費用	11,267,726	75.85	9,110,881	74.05	14,631,056	79.81	3,900,383	79.72
	合計	14,854,634	100.00	12,303,734	100.00	18,332,497	100.00	4,892,754	100.00
合計	原物料	4,837,112	15.06	4,652,160	15.73	4,382,177	12.63	1,059,419	12.73
	直接人工	1,534,564	4.78	1,312,324	4.44	1,469,927	4.24	396,657	4.77
	製造費用	25,739,726	80.16	23,609,004	79.83	28,854,866	83.13	6,864,946	82.50
	合計	32,111,402	100.00	29,573,488	100.00	34,706,970	100.00	8,321,022	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司之主要從事半導體晶圓代工服務、包裝元件及其他設計服務，晶圓代工主要可分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體晶圓代工業務，其主係依客戶需求而客製化之商品，因應客戶對邏輯及記憶體之需求量配置調整產線。由於半導體晶圓代工為資本密集產業需投入龐大機器設備，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季成本結構中，製造費用所占比例最高，分別占銷貨成本之 80.16%、79.83%、83.13%及 82.50%，其中製造費用 109 年度開始較其他年度明顯增加，主係因邏輯 IC 出貨暢旺產能利用率提升，故生產加工用之間接材料(光阻、氣體及化學品等)及生產設備折舊及維修所耗用之設備維修品隨之增加所致；其次為原料，占比分別為 15.06%、15.73%、12.63%及 12.73%，107~108 年度原料金額主係受到矽晶圓市場供需缺口嚴重，使矽晶圓價格上漲，於 109 年度原料價格

回穩，故整體採購單價仍較低；而其成本結構中之直接人工所占比例最小，分別為4.78%、4.44%、4.24%及 4.77%，整體占比亦較為穩定。

該公司及其子公司考量記憶體價格波動過大所產生之營運風險，於 108 年度開始調整產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，以降低記憶體產品價格變動對該公司及其子公司獲利之影響，並運用 12 吋產能與同業的 8 吋產能競爭，發揮成本優勢以提高毛利率。整體而言，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之原料、人工及製造費用比重結構大致相同，其成本變化尚無重大異常之情事。

2.符合「有價證券上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，發行公司與地主之分配比率是否合理

該公司及其子公司非屬「有價證券上市審查準則」第十六條規定之建設公司，故不適用本項評估。

(五)匯率變動情形

1.最近三年度及申請年度截至最近期止合併內外銷、內外購比率以分析匯率變動對發行公司營運之風險

(1)內外銷金額及比例

單位：新臺幣仟元；%

項目		107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至 3 月	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
內銷		30,730,668	61.57	23,480,915	65.41	32,938,268	72.10	9,651,353	72.90
外銷	亞洲	8,265,107	16.56	5,114,172	14.25	9,367,146	20.50	2,511,483	18.97
	美洲	977,228	1.96	387,009	1.08	740,317	1.62	182,113	1.38
	歐洲	9,940,776	19.91	6,915,025	19.26	2,638,884	5.78	894,111	6.75
	小計	19,183,111	38.43	12,416,206	34.59	12,746,347	27.90	3,587,707	27.10
合計		49,913,779	100.00	35,897,121	100.00	45,684,615	100.00	13,239,060	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

單位：新臺幣仟元；%

項目		107 年度			108 年度			109 年度			110 年截至 3 月		
		金額		%	金額		%	金額		%	金額		%
		原幣	本幣		原幣	本幣		原幣	本幣		原幣	本幣	
銷售	美元	1,642,033	49,331,990	98.83	1,159,512	35,861,526	99.90	1,544,468	45,683,615	100.00	466,106	13,239,060	100.00
	新臺幣	581,789	581,789	1.17	35,595	35,595	0.10	1,000	1,000	0.00	—	—	0.00
合計		—	49,913,779	100.00	—	35,897,121	100.00	—	45,684,615	100.00	—	13,239,060	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)內外購金額及比例

單位：新臺幣仟元；%

項目		107 年度		108 年度		109 年度		110 年第一季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
內購	新臺幣	5,073,611	29.34	4,759,022	29.78	5,602,483	31.90	1,266,635	32.20
	美元	9,406,029	54.39	8,329,617	52.13	7,812,619	44.49	1,684,607	42.83
	歐元	1,925	0.01	4,574	0.03	431	0.00	37	0.00
	日幣	2,346,286	13.57	2,339,972	14.64	2,615,869	14.90	502,778	12.78
	小計	16,827,851	97.31	15,433,185	96.58	16,031,401	91.29	3,454,057	87.82
外購	新臺幣	411	0.01	617	0.01	1,518	0.01	527	0.01
	美元	299,865	1.73	356,723	2.23	1,270,528	7.24	429,404	10.92
	歐元	3,168	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	日幣	161,348	0.93	189,097	1.18	257,227	1.46	49,139	1.25
	小計	464,791	2.69	546,437	3.42	1,529,273	8.71	479,070	12.18
合計		17,292,642	100.00	15,979,622	100.00	17,560,674	100.00	3,933,127	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司於 107~109 年度及 110 年第一季之內銷占整體營業收入

比重分別為 61.57%、65.41%、72.10%及 72.90%，外銷市場包括亞洲、美洲及歐洲等地區，不論內外銷交易主要計價幣別皆係美元，107~109 年度及 110 年第一季以美元計價之銷貨金額整體營業收入比重分別為 98.83%、99.90%、100.00%及 100.00%；在採購方面，該公司及其子公司以內購為主，107~109 年度及 110 年第一季內購比重分別為 97.31%、96.58%、91.29%及 87.82%，採購付款幣別亦以美元為主，107~109 年度及 110 年第一季以美元計價之進貨金額占總採購金額比率分別為 56.12%、54.36%、51.73%及 53.75%，其餘約 30%以新臺幣計價，約 15%以日圓支付。以美元計價之應收款項與應付款項相互沖抵可產生一定之自然避險效果，惟該公司及其子公司外幣收入大於外幣支出，無法互抵之美元應收款項在轉換成新臺幣時，因而產生匯兌損益，綜上評估，顯示該公司及其子公司匯兌損益主要受到美元匯率變動之影響。

(3)匯兌損益占營收淨額及營業利益之比例

單位：新臺幣仟元

項目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
兌換利益(損失)淨額(A)	166,282	(68,070)	(316,469)	(54,809)
營業收入淨額(B)	49,913,779	35,897,121	45,684,615	13,239,060
營業淨利(損失)(C)	8,886,597	(2,098,779)	5,744,244	2,840,356
占營業收入之比率(%)(A)/(B)	0.33%	(0.19%)	(0.69%)	(0.41%)
占營業淨利(損失)之比率(%)(A)/(C)	1.87%	(3.24%)	(5.51%)	(1.93%)

資料來源：該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司及其子公司於 107~109 年度及 110 年第一季之兌換利益(損失)淨額分別為 166,282 仟元、(68,070)仟元、(316,469)仟元及(54,809)仟元，占營業收入之比率分別為 0.33%、(0.19%)、(0.69%)及(0.41%)，占營業淨利(損失)之比率則分別為 1.87%、(3.24%)、(5.51%)及(1.93%)；該公司及其子公司產生之兌換損益主要係美元銷貨所產生。107 年度美國國內經濟增長強勁、聯準會持續升息，致美元平穩升值，進而產生淨兌換利益；108 年度受到美國聯準會三度降息之影響，致美元貶值，進而產生淨兌換損失；109 年度受到新冠肺炎疫情影響，對經濟產生巨大的衝擊，美國貨幣政策因此轉向寬鬆，且是無限量化寬鬆，致美元持續貶值，對於持有美元淨資產部位不利，因此持續產生兌換損失。惟該公司及其子公司進行衍生性工具交易，賣出美元遠期外匯以規避營業活動所暴露之匯率風險，以降低匯率波動之影響。

綜上所述，該公司及其子公司兌換損益之變化情形與匯率變動趨勢尚屬合理，各年度兌換(損)益占各年度合併營收淨額比率及營業利益影響有限，該公司及其子公司針對外幣資產負債匯率之風險管理除部分採自然避險外，並密切留意國際金融狀況，掌握最新之匯率市場變動，並請往來銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率走勢，並視實際外幣部位和資金狀況，於政策許可之範圍內，配合遠期外匯合約以規避匯率風險。

2.因應匯率變動之具體措施

該公司及其子公司銷售皆以美元計價為主，採購約 50%以美元支付及約 15%以日圓支付因此產生外幣負債部位；另由於美元銷貨金額較進貨金額高，在外幣應收付款項互相沖抵後，仍有美元資產淨部位，故外幣匯率波動亦會產生匯兌損益，該公司及其子公司採取下列因應措施以降低匯率變動對其產生之影響：

(1)匯率風險用外幣資產及負債自然避險為主，對於銷貨、進貨及資本支出均有一定比重以外幣計價，其整體對於匯率變動之影響可達到部分相互平衡之效果。

(2)財務單位因應金融市場變化，隨時彙集相關資訊，判斷趨勢及風險評估，熟悉金融產品及法令規定，考量該公司及其子公司整體相關部位，編製操作策略方案，為規避風險之依據。

(3)財務單位依授權權限，進行各項避險交易，就公司之已持有之外幣資產及負債部位，以及預期未來之外幣資產及負債部位，評估後與金融機構議定遠期外匯合約，以降低匯率波動風險對公司營運產生之影響。

(4)業務單位向客戶報價及採購單位對外採購時，均會考慮匯率之波動幅度，適時反應調整價格，減緩匯率變化對公司獲利之衝擊。

(5)該公司及其子公司訂有「取得或處分資產處理程序」，規範有關衍生性金融商品之交易原則與方針、風險管理措施等作業程序，並經股東會決議通過，作為從事衍生性金融商品相關作業之依據必要措施。

參、業務狀況

一、營業概況

(一)最近期及最近三個會計年度主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者)之變化分析

1.最近期及最近三個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述該公司之銷售政策。

(1)最近期及最近三個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新臺幣仟元；%

排名	107 年度				108 年度				109 年度				110 年第一季			
	名稱	金額	比例	與發行公司之關係	名稱	金額	比例	與發行公司之關係	名稱	金額	比例	與發行公司之關係	名稱	金額	比例	與發行公司之關係
1	H 公司	9,870,890	19.78	無	H 公司	6,467,776	18.02	無	I 公司	7,721,858	16.90	無	I 公司	1,583,986	11.96	無
2	I 公司	6,443,299	12.91	無	I 公司	5,180,476	14.43	無	A 公司	4,468,525	9.78	無	A 公司	1,357,075	10.25	無
3	A 公司	3,336,612	6.68	無	A 公司	3,118,477	8.69	無	H 公司	2,530,010	5.54	無	H 公司	888,609	6.71	無
4	B 公司	3,213,770	6.44	無	L 公司	1,858,177	5.18	無	F 公司	1,996,878	4.37	無	智豐	714,387	5.40	註 1
5	C 公司	3,019,619	6.05	無	C 公司	1,747,580	4.87	無	C 公司	1,985,010	4.35	無	F 公司	609,386	4.60	無
6	智豐	2,662,231	5.33	註 1	J 公司	1,621,662	4.52	無	D 公司	1,862,556	4.08	無	K 公司	592,184	4.47	無
7	J 公司	2,298,345	4.60	無	智豐	1,605,063	4.47	註 1	L 公司	1,791,038	3.92	無	D 公司	588,398	4.44	無
8	K 公司	1,810,451	3.63	註 2	D 公司	1,426,453	3.97	無	J 公司	1,646,123	3.60	無	C 公司	575,631	4.35	無
9	L 公司	1,804,855	3.62	無	E 公司	1,274,482	3.55	無	K 公司	1,489,438	3.26	無	L 公司	564,224	4.26	無
10	D 公司	1,605,728	3.22	無	K 公司	1,251,172	3.49	無	E 公司	1,475,836	3.23	無	G 公司	517,882	3.91	無
	小計	36,065,800	72.26		小計	25,551,318	71.19		小計	26,967,272	59.03		小計	7,991,762	60.35	
	其他	13,847,979	27.74		其他	10,345,803	28.81		其他	18,717,343	40.97		其他	5,247,298	39.65	
	合計	49,913,779	100.00		合計	35,897,121	100.00		合計	45,684,615	100.00		合計	13,239,060	100.00	

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：智豐係為實質關係人。

註 2：K 公司係為實質關係人，惟 107 年 9 月 4 日董監改選後為非關係人。

(2)最近期及最近三個會計年度主要銷售對象變化情形之原因分析

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工，包含顯示高壓邏輯製程((High Voltage；主要應用於手機、平板、TV 及電子紙等驅動 IC 及觸控驅動 IC 等產品))、電源管理晶片產品(PMIC；Power Management IC)、分離式元件產品(Discrete)、CMOS 影像感測器產品(CIS；CMOS Image Sensor)、嵌入式非揮發性記憶體之晶圓代工服務；以及記憶體產品晶圓代工，包含動態隨機存取記憶體產品(DRAM)與快閃記憶體產品(NAND Flash、NOR Flash)之晶圓代工服務，銷售對象以半導體產業之 IC 設計公司為主，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之營業收入淨額分別為 49,913,779 千元、35,897,121 千元、45,684,615 千元及 13,239,060 千元，茲將該公司及其子公司之前十大銷售對象之變化情形說明如下：

A.邏輯暨特殊應用產品晶圓代工

(A)A 公司

該公司及其子公司與 A 公司交易始於民國 97 年，主要銷售之產品為大小尺寸之 LCD 驅動 IC。107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 3,336,612 千元、3,118,477 千元、4,468,525 千元及 1,357,075 千元，銷售比重分別為 6.68%、8.69%、9.78%及 10.25%，108 年度邏輯市況較差，致對其銷貨金額相較前一年度微幅減少，109 年度增加主係新冠肺炎疫情延燒帶動居家辦公、遠距教學、宅經濟等消費行為，A 公司受惠於筆電、平板電腦、電競顯示器與手機等相關終端需求增加，致面板驅動 IC 出貨暢旺。110 年第一季銷售金額較去年同期增加，主係延續 109 年度態勢出貨持續暢旺，且晶圓代工整體產能滿載且終端需求增加，帶動市場價格上漲所致。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(B)B 公司

該公司及其子公司與 B 公司交易始於民國 103 年，主要銷售之產品為驅動 IC。107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 3,213,770 千元、1,181,644 千元、373,456 千元及 60,618 千元，銷售比重分別為 6.44%、3.29%、0.82%及 0.46%，銷售金額呈逐年遞減之趨勢，主係 B 公司於 108 年度之後僅出既有產品，後續尚無新產品銜接，對其銷貨收入逐漸減少，致 108 年度之後遂退出前十大之列。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(C)C 公司

該公司及其子公司與 C 公司之交易始於民國 97 年，主要銷售產品為 LCD 驅動 IC。107~109 年度及 110 年第一季對 C 公司銷售金額分別為 3,019,619 千元、1,747,580 千元、1,985,010 千元及 575,631 千元，銷售比重分別為 6.05%、4.87%、4.35%及 4.35%，最近三年度均名列該公司及其子

公司第五大銷售客戶，107 年銷售金額較高主要係新產品線大尺寸面板驅動 IC 打入新客戶，陸續出貨放量所致。108 年度因邏輯市況較差，銷售金額隨之減少。109 年度雖於下半年度市況已逐漸回溫，惟客戶投片較慢，致銷售金額微幅增加。110 年度第一季受惠於終端市場需求拉貨，銷售金額相較去年同期增加，惟因該公司及其子公司對其他銷售客戶銷售金額及比重增加，致排名略降至第七大銷售客戶。其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(D)D 公司

該公司及其子公司與 D 公司交易始於民國 104 年，主要銷售之產品為手機及 RFID 系統 IC 晶片，107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 1,605,728 千元、1,426,453 千元、1,862,556 千元及 588,398 千元，銷售比重分別為 3.22%、3.97%、4.08%及 4.44%。108 年度對其銷貨金額微幅降低，主要係智慧型手機需求放緩所致。109 年度及 110 年第一季主係 RFID 系統 IC 晶片受惠於大宗消費電子商品應用復甦，故銷售金額相較去年同期隨之增加。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(E)E 公司

該公司及其子公司與 E 公司交易始於民國 93 年，主要銷售之產品為 CMOS 影像感測器之晶片，107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 1,127,189 千元、1,274,482 千元、1,475,836 千元及 364,867 千元，銷售比重分別為 2.26%、3.55%、3.23%及 2.76%。主係因 E 公司之 CMOS 影像感測器已經切入美國及中國大陸等各大安防大廠供應鏈，因此受惠於智慧安防需求成長效應，中低畫素影像感測器出貨暢旺，致最近三年度呈穩定成長之趨勢。110 年第一季下降，主係該公司及其子公司產能持續滿載，所以公司調整生產產品組合故出貨相較去年同期減少 55,176 千元，減少幅度為 13.14%，致銷售排名退出前十大之列，其變化情形尚屬合理。

(F)F 公司

該公司及其子公司與 F 公司交易始於民國 101 年，主要銷售之產品為 LCD 驅動 IC 及 TDDI(觸控暨驅動整合晶片)，107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 777,838 千元、113,276 千元、1,996,878 千元及 609,386 千元，銷售比重分別為 1.56%、0.32%、4.37%及 4.60%。108 年度銷售金額較去年同期大幅下降，主要係因該公司及其子公司新舊產品尚未銜接之空窗期所致。而 109 年度銷售金額隨之大幅增加，主要係新產品於 108 年度第四季完成開發，並於該年底已獲得客戶採用，且 109 年度新產品隨智慧手機市場買氣增溫及 5G 滲透率提升發酵並出貨放量所致，躍升為第四大銷貨客戶。110 年第一季承 109 年下半年產業需求持續增溫，驅動 IC、觸控 IC 等產品出貨維持高檔態勢，故 110 年第一季銷售金額相較去年同期成長，名列該公司及其子公司第五大銷售客戶。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(G)G 公司

該公司及其子公司與 G 公司交易始於民國 109 年，主要銷售之產品為電源管理晶片，109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 1,001,600 千元及 517,882 千元，銷售比重分別為 2.19%及 3.91%。109 年度銷售金額為 1,001,600 千元，主係 G 公司於 109 年 6 月將電源管理晶片轉向該公司進行投片生產，隨著投片之產能持續開出逐季放量，110 年第一季躍升為第十大銷貨客戶。

B.記憶體產品晶圓代工

(A)H 公司

該公司及其子公司與 H 公司交易始於民國 95 年，主要銷售產品為記憶體，以標準型 DRAM 產品為主，該公司及其子公司自與 H 公司交易以來已久，均維持良好關係，品質獲得客戶信賴，最近三年度及 110 年第一季皆為該公司及其子公司前十大銷售客戶之列。107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 9,870,890 千元、6,467,776 千元、2,530,010 千元及 888,609 千元，銷售比重分別為 19.78%、18.02%、5.54%及 6.71%，107 及 108 年度為該公司及其子公司銷售第一大銷售客戶，108 年度較 107 年度下降，主係 108 年度因記憶體市場成長趨緩、終端需求降溫等因素，出現供過於求的狀況，致標準型記憶體平均銷售價格下跌，109 年度記憶體市況雖於第四季谷底回升，惟標準型 DRAM 平均報價仍處低檔，且終端需求萎縮致拉貨數量減少，遂退至第三大銷售客戶。110 年第一季銷售金額相較去年同期增加，主係標準型 DRAM 受惠於新冠肺炎疫情持續終端需求持續增溫所致。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(B)I 公司

該公司及其子公司與 I 公司之交易始於民國 90 年，主要銷售產品為記憶體產品晶圓代工，產品包含利基型 DRAM、NAND Flash 及 NOR Flash，以利基型 DRAM 為大宗。107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 6,443,299 千元、5,180,476 千元、7,721,858 千元及 1,583,986 千元，銷售比重分別為 12.91%、14.43%、16.90%及 11.96%。108 年度下降主要係記憶體市場終端需求不振及平均售價跌價致 I 公司營收下滑，向該公司及其子公司採購金額隨之下降。109 年度相較去年同期金額大幅增加，主係 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，且由於三大記憶體廠商(三星、SK 海力士、美光)在 109 年下半年將舊製程利基型 DRAM 產能移轉至 CMOS 影像感測器製程後，使得利基型 DRAM 市場供給產生短缺，I 公司受惠缺貨效應而出貨暢旺。110 年第一季銷售金額 1,583,986 千元，相較去年同期 2,183,030 千元減少 27.44%，主係該公司及其子公司產能持續滿載，110 年第一季產能供貨數量減少所致。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(C)智豐科技股份有限公司(以下簡稱：智豐)

智豐成立於民國 91 年(西元 2002 年)，位於台灣台北市，主要經營業務為電子零組件之銷售業務。

該公司及其子公司與智豐交易始於民國 91 年，主要銷售產品為記憶體，以標準型 DRAM 為主。107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 2,662,231 千元、1,605,063 千元、1,472,901 千元及 714,387 千元，銷售比重分別為 5.33%、4.47%、3.22%及 5.40%。主係 108 年度因記憶體市場成長趨緩、終端需求降溫等因素，出現供過於求的狀況，致平均銷售價格下跌，109 年度記憶體市況雖於第四季谷底回升，惟標準體記憶體平均報價仍處低檔，且終端需求萎縮致拉貨數量減少，遂退出前十大之列。110 年第一季受惠於標準型 DRAM 因新冠肺炎疫情持續推動終端需求暢旺，銷售價格上漲故躍升為第四大銷售客戶。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(D)J 公司

該公司及其子公司與 J 公司交易始於民國 88 年，主要銷售產品為記憶體，以利基型 DRAM 為主，107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 2,298,345 千元、1,621,662 千元、1,646,123 千元及 428,359 千元，銷售比重分別為 4.60%、4.52%、3.60%及 3.24%。108 年度下降主要係記憶體市場終端需求不振及平均售價跌價，致該公司及其子公司銷售予 J 公司金額隨之減少，109 年度雖因第四季利基型記憶體市場回溫，終端需求釋出，惟因 J 公司本身銷售產品品項較少，故銷售金額僅呈小幅成長。110 年第一季相較去年同期增加，主係受惠於記憶體大廠在 109 年下半年持續進行產能調整，利基型 DRAM 供貨量減少，已由供需平衡轉為供給短缺，致利基型記憶體需求及價格均呈增加，惟因 110 年第一季整體營收增加，因此銷售占比降至 3.24%，且在其他銷售客戶比重相對增加之情況下，J 公司銷售排名退出前十大之列。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(E)K 公司

該公司及其子公司與 K 公司交易始於民國 100 年，主要銷售產品為記憶體，以利基型 DRAM 為主，107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 1,810,451 千元、1,251,172 千元、1,489,438 千元及 592,184 千元，銷售比重分別為 3.63%、3.49%、3.26%及 4.47%。108 年度下降主要係記憶體市場終端需求不振及平均售價跌價，致對 K 公司銷售金額隨之減少，109 年度及 110 第一季相較去年同期增加，主係因 109 年第四季記憶體市場回溫，終端需求釋出，故銷售予 K 公司金額隨之成長。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(F)L 公司

該公司及其子公司與 L 公司交易始於民國 102 年，主要銷售產品為記憶體，以利基型 DRAM 為主。107~109 年度及 110 年第一季對其銷售金額分別為 1,804,855 千元、1,858,177 千元、1,791,038 千元及 564,224 千元，銷售比重分別為 3.62%、5.18%、3.92%及 4.26%。雙方合作以來維持良好關係，品質獲得客戶信賴，各年度銷售金額均維持穩定，且均名列該公司及其子公司之前十大銷售客戶，其變化情形尚屬合理。

(3)是否有銷貨集中之風險

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季對前十大銷售客戶之銷售金額分別為 36,065,800 仟元、25,551,318 仟元、26,967,272 仟元及 7,991,762 仟元，銷售比重分別為 72.26%、71.19%、59.03%及 60.35%，且各年度對第一大銷售客戶之銷售比重分別為 19.78%、18.02%、16.90%及 11.96%，並未有單一銷售對象之銷售比重逾 30%以上之銷售客戶，且第一大銷售客戶之銷售比重呈逐年降低之趨勢，整體而言，該公司及其子公司尚無銷貨集中風險之虞。

(4)該公司及其子公司之銷售政策

該公司及其子公司主要營業項目係為晶圓代工產品之研發、生產及銷售，近年來成功從 DRAM 轉型至晶圓代工產業，係台灣主要針對客製化邏輯晶片與先進記憶體之晶圓代工服務為主軸的公司：記憶體產品，分別有 DRAM、NAND Flash 及 NOR Flash 等產品；特殊邏輯產品，則有顯示器驅動 IC、影像感測 IC、電源管理 IC 及嵌入式邏輯 IC 等不同應用之產品。該公司及其子公司基於記憶體技術的優勢基礎，同時亦切入邏輯晶片的市場，且達到記憶體及邏輯晶片彈性調配產能之優勢，未來更將積極朝記憶體與邏輯晶片的異質整合發展趨勢。茲將該公司及其子公司之銷售政策列示如下：

A.在台擁有兩座 12 吋鋁製程之晶圓廠，可開發大規模之高性價比產品，並提高銷售產品之競爭力。

B.啟動 Open Foundry 策略，吸引策略夥伴分攤晶圓代工所需之龐大資本支出，除更增添該公司及其子公司本身營業資金調度之靈活度外，更贏得許多國內外知名廠商長期穩定合作關係，奠定該公司及其子公司長期發展之穩定基礎。

C.具備自主研發的能力，積極快速提供符合客戶需求之客製化產品來確保產品之市場競爭力，透過與客戶緊密合作，以自主開發(Platform)、技術導入共同開發(Port in)、技術移轉(Technology Transfer)三大方向協助銷售客戶快速導入量產。

D.針對品質系統亦遵循 ISO 9001、IATF 16949、IECQ QC 080000、ISO 14001、ISO45001 等國際標準，符合全球客戶出貨法規，品質穩定，深受國內外大廠信賴。

2.最近期及最近三個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析最近期及最近三個會計年度主要供應商之變化情形

(1)最近期及最近三個年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新臺幣仟元；%

排名	107 年度				108 年度				109年度				110年第一季			
	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係
1	甲公司	2,522,517	14.59	無	甲公司	2,025,643	12.68	無	甲公司	1,588,215	9.04	無	乙公司	356,515	9.07	無
2	乙公司	1,644,860	9.51	無	丙公司	1,468,660	9.19	無	乙公司	1,557,851	8.87	無	丙公司	351,343	8.93	無
3	丙公司	1,509,364	8.73	無	乙公司	1,331,234	8.33	無	丙公司	1,525,403	8.69	無	甲公司	345,470	8.78	無
4	丁公司	847,321	4.90	無	丁公司	853,031	5.34	無	丑公司	925,343	5.27	無	丁公司	195,213	4.96	無
5	戊公司	719,465	4.16	無	壬公司	676,556	4.23	無	丁公司	865,756	4.93	無	卯公司	167,426	4.26	無
6	己公司	611,686	3.54	無	戊公司	674,599	4.22	無	己公司	600,637	3.42	無	丑公司	155,019	3.94	無
7	庚公司	599,210	3.46	無	己公司	583,432	3.65	無	辛公司	527,429	3.00	無	寅公司	148,110	3.77	無
8	辛公司	560,377	3.24	無	辛公司	522,185	3.27	無	寅公司	459,018	2.61	無	己公司	144,079	3.66	無
9	壬公司	532,598	3.08	無	庚公司	343,116	2.15	無	卯公司	455,945	2.60	無	辛公司	98,462	2.50	無
10	癸公司	333,379	1.93	無	癸公司	335,651	2.10	無	辰公司	385,398	2.20	無	辰公司	94,957	2.42	無
	小計	9,880,777	57.14		小計	8,814,107	55.16		小計	8,890,995	50.63		小計	2,056,594	52.29	
	其他	7,411,865	42.86		其他	7,165,515	44.84		其他	8,669,679	49.37		其他	1,876,533	47.71	
	合計	17,292,642	100.00		合計	15,979,622	100.00		合計	17,560,674	100.00		合計	3,933,127	100.00	

資料來源：該公司及其子公司提供。

(2)發行公司最近期及最近三個會計年度主要供應商之變化情形

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務、包裝元件及其他設計服務，晶圓代工主要可分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體晶圓代工業務，故該公司及其子公司主要進貨項目為矽晶圓與零配件，其他進貨項目為光阻、各類化學品等。107~109 年度及 110 年第一季之前十大進貨金額分別為 9,880,777 千元、8,814,107 千元、8,890,995 千元及 2,056,594 千元，占各期進貨淨額比重分別為 57.14%、55.16%、50.63%及 52.29%。茲就該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季主要供應商之變化情形分析說明如下：

A.甲公司

該公司及其子公司自民國 101 年開始與甲公司交易往來，主要向甲公司採購 8 吋及 12 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 2,522,517 千元、2,025,643 千元、1,588,215 千元及 345,470 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 14.59%、12.68%、9.04%及 8.78%，供應商排名 107~109 年度皆為第一大供應商，110 年第一季則為第三大供應商，主係雙方長期維持穩定合作關係，於品質、產量及交期上較能配合該公司及其子公司需求，而進貨淨額及比率逐年降低主係該公司及其子公司積極分散供貨來源，開發其他合格供應商，加上矽晶圓採購價格於 109 年開始下降，故對其進貨淨額及比率亦隨之降低。

B.乙公司

該公司及其子公司自民國 93 年開始與乙公司交易往來，主要向乙公司採購 8 吋及 12 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 1,644,860 千元、1,331,234 千元、1,557,851 千元及 356,515 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 9.51%、8.33%、8.87%及 9.07%，供應商排名 107~109 年度及 110 年第一季分別占第二大、第三大、第二大及第一大，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係，主係乙公司於品質、產量及交期上較能配合該公司及其子公司需求，整體而言，對其採購金額及比率尚無重大異常情形。

C.丙公司

該公司及其子公司自民國 97 年開始與丙公司交易往來，主要向丙公司購買零配件及石英等矽晶圓加工所需耗材，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 1,509,364 千元、1,468,660 千元、1,525,403 千元及 351,343 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 8.73%、9.19%、8.69%及 8.93%，供應商排名 107~109 年度及 110 年第一季分別占第三大、第二大、第三大及第二大，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係，主係該公司及其子公司生產設備向其購買，故於生產設備維護時，會優先採購原廠提供的設備維修品，加上丙公司提供之設備維修品於品質方面也優於其他供應商，整體而言，對其採購金額及比率尚無重大異常情形。

D.丁公司

該公司及其子公司自民國 95 年開始與丁公司交易往來，主要向丁公司採購半導體材料，包含光阻劑、石英、IC 製程用化學品與特殊氣體等用於晶圓加工所需，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 847,321 千元、853,031 千元、865,756 千元及 195,213 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 4.90%、5.34%、4.93%及 4.96%，供應商排名 107~108 年度及 110 年第一季為第四大供應商，109 年度為第五大供應商，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係，主係丁公司於早期便取得該公司及其子公司合格供應商資格，提供之半導體材料主要為光阻劑，因晶圓代工大多為客製化製程，各製程對於光罩及光阻劑需求皆有其特定性，故整體變化會隨使用該光阻劑之產品變動銷量變動，若銷貨訂單及供貨來源品質無重大變化時，對其採購金額及比率便會維持穩定，整體無重大異常情形。

E.戊公司

該公司及其子公司自民國 88 年開始與戊公司交易往來，主要向戊公司購買生產設備維修所耗用之設備維修品，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 719,465 千元、674,599 千元、34,598 千元及 6,715 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 4.16%、4.22%、0.20%及 0.17%，供應商排名 107~108 年度分別占第五大及第六大，採購金額逐漸降低主要係戊公司為丑公司之代理商，109 年開始原廠丑公司策略調整，將機台及零配件業務轉為原廠直售，故於 109 年度退出前十大供應商之列。

F.己公司

該公司及其子公司自民國 85 年開始與己公司交易往來，向己公司購買 8 吋矽晶圓、光阻劑、石英、氣體、化學品等，並以光阻劑為主要採購項目，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 611,686 千元、583,432 千元、600,637 千元及 144,079 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.54%、3.65%、3.42%及 3.66%，供應商排名 107~109 年度及 110 年第一季分別占第六大、第七大、第六大及第八大，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係，係因己公司主要代理庚公司之產品，其光阻劑之品質穩定且能配合公司交期，因晶圓代工大多為客製化製程，各製程對於光罩及光阻劑需求皆有其特定性，故整體變化會隨使用該光阻劑之產品變動銷量變動，若銷貨訂單及供貨來源品質無重大變化時，對其採購金額及比率便會維持穩定，整體而言，對其採購金額及比率穩定尚無重大異常情形。

G.庚公司

該公司及其子公司自民國 90 年開始與庚公司交易往來，主要向庚公司購買 8 吋及 12 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 599,210 千元、343,116 千元、118,056 千元及 13,871 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.46%、2.15%、0.67%及 0.35%，供應商排名 107~108 年度分

別為第七大及第九大供應商，對其進貨淨額及比率逐年下降係因庚公司提供之矽晶圓報價相對其他供應商逐漸較不具價格優勢，故自 109 年度起退出前十大供應商之列。

H.辛公司

該公司及其子公司自民國 97 年開始與辛公司交易往來，主要向辛公司購買零配件及石英等矽晶圓加工所需耗材，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 560,377 千元、522,185 千元、527,429 千元及 98,462 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.24%、3.27%、3.00%及 2.50%，供應商排名 107~108 年度為第八大供應商，109 年度及 110 年第一季則分別為第七大及第九大供應商，對其進貨淨額及比例維持穩定合作關係，整體而言尚無重大異常情形。

I.壬公司

該公司及其子公司自民國 97 年開始與壬公司交易往來，主要向壬公司購買 8 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 532,598 千元、676,556 千元、173,381 千元及 0 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.08%、4.23%、0.99%及 0.00%，供應商排名 107~108 年度分別占第九大及第五大，109 年開始係因將 8 吋矽晶圓銷售業務轉給其子公司卯公司，故進貨淨額及比率逐漸降低，致壬公司退出前十大供應商之列。

J.癸公司

該公司及其子公司自民國 88 年開始與癸公司交易往來，主要向癸公司購買光阻劑，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 333,379 千元、335,651 千元、357,262 千元及 81,952 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.93%、2.10%、2.03%及 2.08%，供應商排名 107~108 年度皆為第十大，而 109 年度採購金額仍維持穩定，惟 109 年及 110 年第一季採購總進貨淨額上升，故退出前十大供應商之列，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係。

K.丑公司

該公司及其子公司自民國 108 年開始與丑公司交易往來，主要向丑公司購買晶圓代工所需之零配件，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 0 千元、72,307 千元、925,343 千元及 155,019 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、0.45%、5.27%及 3.94%，109 年度及 110 年第一季進貨淨額及比例大幅提升，主係戊公司為丑公司之代理商，109 年開始因原廠丑公司進行策略調整，將機台及零配件業務轉為原廠直售，使丑公司於 109 年度及 110 年第一季分別成為第四大及第六大供應商。

L.寅公司

該公司及其子公司自民國 105 年開始與寅公司交易往來，主要向寅公司購買 8 吋及 12 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為

107,635 千元、150,431 千元、459,018 千元及 148,110 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0.62%、0.94%、2.61%及 3.77%，對其進貨淨額及比率逐年提高，主係因 109 年開始因銷貨端產品組合改變，使用寅公司供給之矽晶圓加工產品銷量提高，故於 109 年度開始進入前十大供應商之列。

M.卯公司

該公司及其子公司自民國 109 年開始與卯公司交易往來，主要向卯公司購買 8 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 0 千元、0 千元、455,945 千元及 167,426 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、0%、2.60%及 4.26%，109 年係因母公司壬公司將 8 吋矽晶圓銷售業務轉給卯公司，故向其開始採購 8 吋矽晶圓，故向卯公司進貨淨額及比例逐漸增加，於 109 年度及 110 年第一季分別為第九大及第五大供應商。

N.辰公司

該公司及其子公司自民國 93 年開始與辰公司交易往來，主要向辰公司購買矽晶圓加工所需之研磨片及研磨液，107~109 年度及 110 年第一季對其進貨淨額分別為 317,734 千元、285,378 千元、385,398 千元及 94,957 千元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.84%、1.79%、2.20%及 2.42%，進貨淨額及比率維持穩定合作關係。

(3)進貨政策及是否有進貨集中之風險

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年度第一季對前十大供應商之進貨淨額比例分別為 57.14%、55.16%、50.63%及 52.29%；107~109 年度及 110 年度第一季來自第一大供應商之比重分別為 14.59%、12.68%、9.04%及 9.07%，顯見其供應商尚屬分散。其中矽晶圓均有二家以上之供應商，而零配件及其他生產原料，如：光阻、氣體、化學品及消耗材料等，品項分散且原物料種類繁多，亦無進貨集中之情形，故評估該公司及其子公司應無進貨集中之風險。

(4)供貨來源穩定性之評估

該公司及其子公司主要原料為矽晶圓及零配件，其供應商多為業界知名廠商，且上游原料供應商眾多，是以採購單位進行原料採購會考量市場供需、品質狀況、供應商產能及產品組合等，決定最佳採購量。為靈活調整採購來源及採購量，且分散進貨過度集中風險，主要原料採購均維持二家以上之供應商，並皆維持長期往來之合作關係，截至評估報告出具日止，並無供貨短缺或中斷情形發生。

(二)最近期及最近三個會計年度，發行公司之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.最近期及最近三個會計年度，發行公司之財務報告應收款項變動之合理性、備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

該公司及其子公司合併報表編製主體包含該公司本身暨其轉投資公司 Global Powertec Co., Ltd.(以下簡稱 Global Powertec)、PowerMemory Inc.(以下簡稱 Power Memory)及 Maxram Inc.(以下簡稱 Maxram)。其中該公司統籌集團經營策略，主要負責晶圓代工業務，包含記憶體及邏輯 IC 之研發、生產及銷售，而集團子公司依其定位各有不同，Global Powertec 屬投資控股公司，並無實質營運；PowerMemory 及 Maxram 則分別負責 Flash 及 DRAM 製程相關設計及研發，故合併應收款項主要僅來自於該公司本身。以下僅就該公司最近期及最近三個會計年度所出具之合併財務報告進行應收款項變動之合理性、備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估。

(1)應收款項變動之合理性

單位：新臺幣仟元

項目＼期間		107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
營業收入淨額		49,913,779	35,897,121	45,684,615	13,239,060
應收款項總額	應收票據	—	—	—	—
	應收帳款	6,251,317	5,344,970	5,981,210	7,043,017
	應收帳款-關係人	129,542	49,914	253,494	304,412
	小計	6,380,859	5,394,884	6,234,704	7,347,429
備抵損失提列數		—	—	—	—
應收款項淨額		6,380,859	5,394,884	6,234,704	7,347,429
應收款項週轉率(次)		8.50	6.10	7.86	7.80
應收款項收現天數(天)		43	60	47	47
授信條件		考量個別客戶資本額、營運規模、財務狀況及過往交易情形、收款記錄等而給予不同之授信條件，收款條件主要為月結 30 天～60 天。			

資料來源：各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之營業收入淨額分別為 49,913,779 仟元、35,897,121 仟元、45,684,615 仟元及 13,239,060 仟元，期末應收款項總額分別為 6,380,859 仟元、5,394,884 仟元、6,234,704 仟元及 7,347,429 仟元，108 年底應收款項總額較 107 年底減少 985,975 仟元，減少幅度為 15.45%，主係 108 年度由於邏輯及記憶體產品終端客戶需求減少，加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換，且產品的市況不佳，使 108 年底應收款項隨之減少，惟減少幅度不若整體營收，主係 108 年第四季營業收入已有逐步恢復所致。109 年底應收款項總額較 108 年底增加 839,820 仟元，成長幅度為 15.57%，主係邏輯 IC 出貨暢

旺且記憶體報價自谷底回溫，致期末應收款項亦隨之增加。110 年第一季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，營業收入相較去年同期增加 23.58%，使應收帳款總額較 109 年底增加 17.85%。整體而言，該公司及其子公司最近三年度合併應收款項變化情形主係隨合併營業收入變化而變動，尚無重大異常。

在應收款項週轉率方面，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季應收款項週轉率分別為 8.50 次、6.10 次、7.86 次及 7.80 次，應收款項收現天數分別為 43 天、60 天、47 天及 47 天，介於正常授信期間內，尚無重大異常之情事。108 年度合併應收帳款週轉率較 107 年度下降，主係該公司及其子公司受驅動 IC 產品新舊技術平台轉換且記憶體價格下滑影響，使得 108 年度營業收入因而減少，且減少之幅度較 108 年度平均應收款項減少幅度大，致應收款項收現天數上升。109 年度應收款項週轉率較 108 年度上升，主係邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫使得營業收入增加，且增加之幅度較 109 年平均應收款項增加幅度大，致應收款項收現天數下降。110 年第一季承 109 年下半年出貨暢旺態勢，應收款項週轉率與 109 年度差異不大。整體而言，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之應收款項收現天數落在 43~60 天，與主要授信條件相當，尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三個會計年度之應收款項總額變動及應收款項週轉率變化情形應屬合理，尚無重大異常之情事。

(2)備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估

A.備抵損失提列政策

該公司及其子公司採用 IFRS 9 之公報規定，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，係按代表客戶依據信用條件支付所有到期金額能力之共同信用風險特性，並已納入前瞻性之資訊，包括總體經濟及所屬半導體相關產業資訊。並使用準備矩陣提列預期信用損失，計算出過去期間歷史違約率，及考量前瞻性調整後，依應收款項逾期天數分組進行準備矩陣計算，據以評估備抵損失應提列之金額。此外，該公司及其子公司亦考量個別客戶違約紀錄與現時財務狀況，若有相當資訊足以確認個別客戶之應收款項未來收回可能性不大者，將個別提列備抵損失。

帳齡		平均推估損失率			
		107 年度適用	108 年度適用	109 年度適用	110 年第一季適用
未逾期		0%	0%	0%	0%
逾期	1-30 天	0%	0%	0%	0%

帳齡		平均推估損失率			
		107 年度適用	108 年度適用	109 年度適用	110 年第一季適用
	31-60 天	0%	0%	0%	0%
	61-90 天	0%	0%	0%	0%
	91-120 天	0%	0%	0%	0%
	121-150 天	0%	0%	0%	0%
	151-180 天	0%	0%	0%	0%
	超過 180 天以上	0%	0%	0%	0%

資料來源：該公司及其子公司提供。

B.備抵損失提列之適足性

單位：新臺幣仟元

項目	107 年底	108 年底	109 年底	110 年第一季
應收款項總額(B)	6,380,859	5,394,884	6,234,704	7,347,429
備抵損失金額(A)	—	—	—	—
備抵損失提列比率(A)/(B)	0%	0%	0%	0%

資料來源：各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司依據客戶過往交易情形、銷售能力、財務及經營狀況，綜合考量後定交易條件，定期檢視逾期應收款項進行催收，以防範異常帳款之發生，降低未來帳款無法回收可能性；另依據應收款項帳齡及過去對客戶之收款經驗，訂定應收帳款/應收票據減損提列細則，並個別檢視應收款項客戶提列備抵損失金額。該公司及其子公司 107~109 年底及 110 年 3 月底依據收款情形評估並無提列備抵損失金額，經檢視該公司及其子公司之主要銷售客戶多為國內外知名大廠，營運規模、財務狀況及長期往來信用良好，帳款品質穩定，且最近三年度及 110 年第一季並無實際發生備抵損失。整體而言，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季提列之備抵損失金額尚依所訂之政策執行，應已涵蓋帳款未能收回之風險，經評估其備抵損失適足性尚無疑慮。

C.應收款項收回可能性評估

單位：新臺幣仟元

項目	110 年 3 月底	截至 110 年 6 月底之收回情形			
		收回金額	收回比率(%)	未收回金額	未收回比率(%)
應收帳款	7,347,429	7,347,429	100	—	—

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司 110 年 3 月底之應收帳款及應收帳款關係人分別為 7,043,017 仟元及 304,412 仟元，截至 110 年 6 月底止，應收款項業已全數收回。此外，107~109 年度及 110 年第一季並未有實際發生壞帳之情形，故應收

款項收回應屬無虞。整體而言，該公司及其子公司應收款項收回情形尚屬良好，並無重大無法收回疑慮之情事。

(3)與同業比較

單位：新臺幣仟元；次；天；%

項目 \ 年度		107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
營業收入	力積電	49,913,779	35,897,121	45,684,615	13,239,060
	聯電	151,252,571	148,201,641	176,820,914	47,097,012
	世界	28,928,094	28,286,072	33,131,202	9,180,131
	華邦電	51,190,323	48,771,434	60,683,171	21,325,358
應收款項總額	力積電	6,380,859	5,394,884	6,234,704	7,347,429
	聯電	23,923,171	26,426,336	27,479,357	29,430,849
	世界	5,731,976	4,968,945	5,734,253	6,293,881
	華邦電	6,668,868	6,279,259	10,051,897	11,082,949
備抵損失帳列金額	力積電	—	—	—	—
	聯電	48,152	697,590	206,084	193,841
	世界	3,872	731	731	731
	華邦電	155,158	148,353	266,759	278,550
應收款項淨額	力積電	6,380,859	5,394,884	6,234,704	7,347,429
	聯電	23,875,019	25,728,746	27,273,273	29,237,008
	世界	5,728,104	4,968,214	5,733,522	6,293,150
	華邦電	6,513,710	6,130,906	9,785,138	10,804,399
應收款項週轉率(次)	力積電	8.50	6.10	7.86	7.80
	聯電	6.59	5.89	6.56	6.62
	世界	5.90	5.29	6.19	6.11
	華邦電	7.55	7.53	7.43	8.07
應收款項週轉天數(天)	力積電	43	60	47	47
	聯電	56	62	56	56
	世界	62	69	59	60
	華邦電	49	49	50	46
備抵損失占應收帳款之比重(%)	力積電	—	—	—	—
	聯電	0.20	2.64	0.75	0.66
	世界	0.07	0.01	0.01	0.01
	華邦電	2.33	2.36	2.65	2.51

資料來源：各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之應收款項週轉率分別為 8.50 次、6.10 次、7.86 次及 7.80 次，應收款項收現天數分別為 43 天、60 天、47 天及 47 天，該公司及其子公司最近三年度及 110 年第一季合併應收款項變化情

形主係隨合併營業收入變化而變動。與採樣同業相較，該公司及其子公司 107 及 109 年度應收款項週轉率均優於採樣同業，108 年度及 110 年第一季應收款項週轉率及收現天數均介於採樣同業之間，採樣同業間應收款項週轉情形差異主係因各公司之營運規模、收款政策及客戶組成不同所致，尚無重大異常之情事。

在備抵損失提列金額方面，該公司及其子公司 107~109 年底及 110 年 3 月底依據收款情形評估並無提列備抵損失金額。與採樣同業相較，該公司及其子公司因無提列備抵損失金額，故提列比率均低於所有採樣同業，主係因該公司及其子公司依照公司政策執行收款，於 107~109 年度及 110 年第一季並無發生實際呆帳損失之情形，且期後實際收回情形尚屬良好，故備抵損失提列適足性尚屬允當，並無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司備抵損失之提列係依據公司訂定之政策並參考客戶實際經營狀況與帳款收現情形予以評價，加上期後收回情形尚屬良好，其備抵損失提列情形應無重大異常之情事，另與採樣同業相較，該公司及其子公司應收款項週轉率及週轉天數均介於採樣同業之間，故尚無重大異常之情事。

2.最近期及最近三個會計年度個體財務報告應收款項變動之合理性、備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

相關評估請參閱前述「(一)、1. 最近期及最近三個會計年度，發行公司之財務報告應收款項變動之合理性、備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估」說明。

二、存貨概況

(一)最近期及最近三個會計年度，發行公司之財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

該公司及其子公司合併報表編製主體包含該公司本身暨其轉投資公司 Global Powertec Co., Ltd.(以下簡稱 Global Powertec)、PowerMemory Inc.(以下簡稱 Power Memory)及 Maxram Inc.(以下簡稱 Maxram)。其中該公司統籌集團經營策略，主要負責晶圓代工業務，包含記憶體及邏輯 IC 之研發、生產及銷售，而集團子公司依其定位各有不同，Global Powertec 屬投資控股公司，並無實質營運；PowerMemory 及 Maxram 則分別負責 Flash 及 DRAM 製程相關設計及研發，故合併存貨主要僅來自於該公司本身。

1.最近期及最近三個會計年度發行公司財務報告存貨淨額變動之合理性

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
營業收入淨額	49,913,779	35,897,121	45,684,615	13,239,060
營業成本	34,633,514	32,896,453	34,692,204	8,804,380
原料	2,584,163	2,317,005	3,111,065	3,259,307

在製品	4,073,109	4,460,246	4,533,721	4,523,043
製成品	981,464	854,139	938,400	628,581
期末存貨總額	7,638,736	7,631,390	8,583,186	8,410,931
備抵存貨跌價及呆滯損失	(894,961)	(1,245,893)	(764,575)	(649,401)
期末存貨淨額	6,743,775	6,385,497	7,818,611	7,761,530
存貨週轉率(次)	5.39	5.01	4.88	4.52
存貨週轉天數(天)	68	73	75	81

資料來源：107~109 年度及 110 年第一季係經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司主從事半導體晶圓代工服務，其原物料主要為矽晶圓、零配件、光阻、氣體、化學品及消耗材料等；製成品為記憶體產品與邏輯暨特殊應用產品；在製品為尚須製程加工及尚未完工產品之料件等，該公司及其子公司之產品主依銷售客戶訂單需求而備料生產，針對主要原料矽晶圓係以二至三個月安全庫存進行備料，製成品則考量製程之生產週期以一至三個月進行備貨，故其存貨變化與客戶訂單需求關係密切。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之存貨淨額為 6,743,775 仟元、6,385,497 仟元、7,818,611 仟元及 7,761,530 仟元，其中 108 年底存貨淨額下降主係 108 年度記憶體市況不佳，標準型記憶體價格下跌，使該公司及其子公司標準型記憶體部分之存貨產生較高之存貨跌價損失，而 109 年底開始明顯呈現上升之趨勢，主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價至自谷底回溫，且為因應 110 年度訂單需求，故增加原料備貨所致，尚無重大異常情事。

在合併存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司及其子公司於 107~109 年度及 110 年第一季之合併存貨週轉率分別為 5.39 次、5.01 次、4.88 次及 4.52 次；週轉天數分別為 68 天、73 天、75 天及 81 天，108 年度存貨週轉率較 107 年度下降，主係該公司及其子公司於 108 年由於邏輯產品客戶需求減少，加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換，且記憶體產品的市況不佳，產品 ASP 下滑，使得整體產能利用率下滑，致當年度營業收入相較 107 年度下降，使相對的銷貨成本減少所致；而 109 年度及 110 年第一季存貨週轉率下降，則主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價至自谷底回溫，自 109 年度開始為因應 110 年度訂單需求故積極增加原料備貨，使平均存貨淨額提升所致。

綜上所述，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之存貨總額、存貨週轉率及週轉天數主係因國際矽晶圓行情、產能規劃及庫存管理等因素影響，其變動情形尚屬合理。

2.備抵存貨跌價與呆滯損失提列政策合理性暨適足性評估

(1)備抵存貨跌價及呆滯損失之提列政策

A.存貨跌價損失提列政策

該公司及其子公司採用國際會計準則公報第二號「存貨」規定，其存貨採用永續盤存制，平時按標準成本計價，結帳日再予以調整使其接近按加權平均法計算之成本，其存貨跌價評估方式，係採成本與淨變現價值孰低法衡量，比較成本與淨變現價值孰低時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

B.存貨呆滯損失提列政策

存貨呆滯損失提列比例如下：

(A)原料細分四類

(a)原料

90 天以下	91-180 天	181 天以上
0%	50%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

(b)物料(石英部分)

365 天以下	366-720 天	721 天以上
0%	50%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

(c)物料(石英除外)

180 天以下	181-365 天	366 天以上
0%	50%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

(d)設備維修備品

365 天以下	366-540 天	541-720 天	721-1080 天	1081-1440 天	1441 天以上
0%	20%	40%	60%	80%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

(B)在製品

因製程較短約 30~90 天，故無提列呆滯損失。

(C)製成品

180 天以下	181-365 天	366 天以上
0%	50%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司經參酌過往經營經驗，訂定存貨備抵跌價及呆滯損失提列政策，除按前揭成本與淨變現價值孰低法評價外，另針對各存貨組成項目庫齡超過一定天期之存貨，評估短期銷售或使用可能性不高時，提列 100%呆滯損失。

綜上評估，該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策係以國際會計準則為依據，並考量所處行業特性、產品性質、產品生命週期及過往產銷經驗

等，經評估尚屬合理，並未發現重大異常之情事。

(2)合併備抵存貨跌價及呆滯損失提列之適足性

單位：新臺幣仟元

項目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	894,961	1,245,893	764,575	649,401
期末存貨總額(B)	7,638,736	7,631,390	8,583,186	8,410,931
提列比率(%) (A)/(B)	11.72	16.33	8.91	7.72

資料來源：107~109 年度及 110 年第一季係經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之備抵存貨跌價及呆滯損失金額分別為 894,961 仟元、1,245,893 仟元、764,575 仟元及 649,401 仟元，占各期期末存貨總額比率分別為 11.72%、16.33%、8.91%及 7.72%。108 年度提列比率增加至 16.33%，主係 108 年度記憶體市況不佳，標準型記憶體價格下跌，使該公司及其子公司標準型記憶體部分之存貨產生較高之存貨跌價損失，隨著近年來邏輯產品營收比重逐年提高，將能有效降低記憶體的價格波動風險。109 年度及 110 年第一季提列比率逐漸下降至 7.72%，主係因 109 年度記憶體報價自谷底回溫，故迴轉備抵存貨所致。該公司及其子公司為滿足客戶需求，提供客製化產品，原物料備料多為因應客戶訂單所需，且經參考存貨庫齡、存貨週轉率及存貨去化比率，該公司及其子公司備抵存貨跌價與呆滯損失提列之金額尚屬適足，且提列之情形無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額尚屬適足，應無重大異常情事。

3.存貨去化情形

單位：新臺幣仟元

項目	110 年 3 月底存貨金額	截至 110 年 6 月底存貨去化情形		截至 110 年 6 月底存貨未去化情形	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
原物料	3,259,307	1,878,811	57.64	1,380,496	42.36
在製品	4,523,043	4,522,054	99.98	989	0.02
製成品	628,581	493,304	78.48	135,277	21.52
合計	8,410,931	6,894,169	81.97	1,516,762	18.03

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司 110 年 3 月底存貨總額為 8,410,931 仟元，截至 110 年 6 月底存貨去化金額為 6,894,169 仟元，去化比率為 81.97%，未去化金額 1,516,762 仟元，未去化比率為 18.03%，茲就各項存貨之去化情形分別說明如下：

(1)原物料

原物料存貨總額為 3,259,307 仟元，占期末存貨總額 38.75%，截至 110 年 6 月底存貨去化金額為 1,878,811 仟元，去化比率為 57.64%。未去化之原物料金額為 1,380,496 仟元，原物料主要為矽晶圓、零配件、光阻、氣體及消耗材料等，主係依據客戶訂單及策略性備料，提前採購所需原物料所致，經評估尚無重大異常情事。

(2)在製品

在製品存貨總額為 4,523,043 仟元，占期末存貨總額 53.78%，截至 110 年 6 月底存貨去化金額為 4,522,054 仟元，去化比率為 99.98%。未去化之在製品金額為 989 仟元，未去化比率微小，故不予進一步分析。

(3)製成品

製成品總額為 628,581 仟元，占期末存貨總額 7.47%，截至 110 年 6 月底存貨去化金額為 493,304 仟元，去化比率為 78.48%。製成品係依照客戶訂單需求及考量公司生產週期安排生產，並受客戶取貨時點及品質檢驗是否合格影響製成品去化進度，截至 110 年 6 月底未去化之製成品金額為 135,277 仟元，主係因部分產品完工後尚未能符合公司品質標準或客戶允收標準，該公司及其子公司已積極處理，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司存貨去化情形尚屬合理，並無異常之情事。

4.與同業比較

單位：新臺幣仟元；次；天；%

項目 \ 年度		107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
營業成本	力積電	34,633,514	32,896,453	34,692,204	8,804,380
	聯電	128,412,544	126,886,669	137,823,813	34,602,710
	世界	18,759,824	17,953,285	21,874,918	5,682,314
	華邦電	32,039,220	35,857,582	43,643,035	13,314,740
期末存貨總額(B)	力積電	7,638,736	7,631,390	8,583,186	8,410,931
	聯電	註 1	註 1	註 1	註 1
	世界	註 1	註 1	註 1	註 1
	華邦電	註 1	註 1	註 1	註 1
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	力積電	894,961	1,245,893	764,575	649,401
	聯電	註 1	註 1	註 1	註 1
	世界	註 1	註 1	註 1	註 1
	華邦電	註 1	註 1	註 1	註 1
期末存貨淨額	力積電	6,743,775	6,385,497	7,818,611	7,761,530
	聯電	18,203,119	21,714,802	22,552,486	22,225,438

項目 \ 年度		107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
	世界	3,415,585	3,107,612	3,072,362	3,348,866
	華邦電	10,908,106	10,332,143	14,141,414	14,480,093
備抵存貨跌價及呆滯損失提列比率(%)(A)/(B)	力積電	11.72	16.33	8.91	7.72
	聯電	註 1	註 1	註 1	註 1
	世界	註 1	註 1	註 1	註 1
	華邦電	註 1	註 1	註 1	註 1
存貨週轉率(次)(註 2)	力積電	5.39	5.01	4.88	4.52
	聯電	7.04	6.36	6.23	6.18
	世界	6.05	5.50	7.08	7.08
	華邦電	3.36	3.38	3.57	3.72
存貨週轉天數(天)	力積電	68	73	75	81
	聯電	52	58	59	60
	世界	61	67	52	52
	華邦電	109	109	103	99

資料來源：107~109 年度及 110 年第一季係經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。
註 1：合併財務報告中並未揭示存貨總額暨備抵存貨跌價及呆滯損失金額。
註 2：存貨週轉率係以營業成本除以平均存貨淨額計算。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之存貨週轉率分別為 5.39 次、5.01 次、4.88 次及 4.52 次，週轉天數分別為 68 天、73 天、75 天及 81 天，該公司及其子公司係以接單式生產及計畫性生產兼具之生產方式安排生產排程及採購作業，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，存貨週轉率主要受到因訂單排程及客製化產品須提前備料，因而略有增減。與採樣同業相較，107~109 年度及 110 年第一季皆介於採樣同業公司間，整體而言尚無重大異常之情事。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之備抵存貨跌價及呆滯損失占存貨總額比率分別為 11.72%、16.33%、8.91%及 7.72%，與採樣同業相較，因同業財務報告皆採淨額表達而無法取具數據，故無法比較分析。由於該公司及其子公司係以訂單式生產及計畫性生產為主，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，產品客製化程度高，具多樣化特性，故其在製品及製成品大多均有明確的客戶訂單歸屬，且該公司之備抵存貨跌價及呆滯損失係以國際財務會計準則為依歸，並參酌過去之經營經驗、各地市場銷售情形及以往年度實際發生存貨呆滯之庫齡，擬訂備抵提列政策後據以提列，經會計師評價備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列金額尚屬適足。

綜上所述，該公司及其子公司備抵損失之提列係依據公司訂定之政策並參考客戶行業特性與存貨情形予以評價，其備抵損失提列情形應無重大異常之情事，另與採樣同業相較，該公司及其子公司存貨週轉率及週轉天數均介於採樣同業之間，故尚無重大異常之情事。

(二)最近期及最近三個會計年度，發行公司之個體財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

相關評估請參閱前述「(一)最近期及最近三個會計年度，發行公司之財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估」說明。

三、最近期及最近三個會計年度之業績概況

(一)列表並說明發行公司最近期及最近三個會計年度營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新臺幣仟元

項目＼年度		107 年度	108 年度		109 年度		110 年第一季	
		金額	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)
營業收入	力積電	49,913,779	35,897,121	(28.08)	45,684,615	27.27	13,239,060	23.58
	聯電	151,252,571	148,201,641	(2.02)	176,820,914	19.31	47,097,012	11.43
	世界	28,928,094	28,286,072	(2.22)	33,131,202	17.13	9,180,131	17.03
	華邦電	51,190,323	48,771,434	(4.73)	60,683,171	24.42	21,325,358	84.65
營業毛利	力積電	15,280,265	3,000,668	(80.36)	10,992,411	266.33	4,434,680	53.94
	聯電	22,840,027	21,314,972	(6.68)	38,997,101	11.93	12,494,302	53.83
	世界	10,168,270	10,332,787	1.62	11,256,284	3.26	3,497,817	43.92
	華邦電	19,151,103	12,913,852	(32.57)	17,040,136	31.95	8,010,618	187.48
營業利益	力積電	8,886,597	(2,098,779)	(123.62)	5,744,244	373.69	2,840,356	72.96
	聯電	5,797,232	4,689,850	(19.10)	22,007,407	11.69	7,621,747	123.25
	世界	7,154,708	6,909,389	(3.43)	7,416,206	1.79	2,450,890	62.46
	華邦電	7,926,697	1,255,209	(84.16)	1,627,291	29.64	2,295,821	7117.52

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工，包含顯示高壓邏輯製程((High Voltage；主要應用於手機、平板、TV及電子紙等驅動 IC 及觸控驅動 IC 等產品)、電源管理晶片產品(Power IC)、分離式元件產品(Discrete)、CMOS 影像感測器產品(CIS；CMOS Image Sensor)、嵌入式非揮發性記憶體之晶圓代工服務；以及記憶體產品晶圓代工，包含動態隨機存取記憶體產品(DRAM)、快閃記憶體產品(NAND Flash、NOR Flash)之晶圓代工服務。

檢視目前上市櫃公司，選樣條件以同屬從事半導體晶圓代工服務或記憶體製造之公司，並參酌營業項目較為相近者，選取聯電(上市公司，股票代號：2303)、世界(上櫃公司，股票代號：5347)及華邦電(上市公司，股票代號：2344)作為採樣公司。其中，聯電主要係提供半導體晶圓代工之服務，專注於邏輯及特殊技術，包含電子行業的各項主要應用產品生產晶片；世界主要係提供半導體晶圓代工之服務，包含邏輯、混合訊號、高壓、超高壓、BCD、SOI、嵌入式非揮發性記憶體等製程，主要代

工產品為 LCD 驅動 IC、電源管理 IC 及指紋辨識 IC 等；華邦電主要從事利基型記憶體 IC 設計、製造與銷售，產品包括利基型記憶體(Specialty DRAM)、行動記憶體(Mobile DRAM)以及編碼型快閃記憶體(Code Storage Flash Memory)等。茲就該公司及其子公司與採樣同業聯電、世界及華邦電之營業收入、營業毛利及營業利益比較說明如下：

1.營業收入

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之營業收入分別為 49,913,779 仟元、35,897,121 仟元、45,684,615 仟元及 13,239,060 仟元，營業收入成長率分別為(28.08)%、27.27%及 23.58%，108 年度營業收入降低 28.08%，主係中美貿易影響半導體產業之不確定性因素繼續蔓延，邏輯產品終端客戶拉貨需求降低，加上記憶體市況不佳、單位售價(ASP)下跌等因素影響，致當年度營業收入相較 107 年度下降 28.08%。109 年度營收較 108 年度增加 9,787,494 仟元，成長幅度為 27.27%，主係邏輯 IC 出貨暢旺，且記憶體報價自谷底回溫，且該公司及其子公司透過優化客戶結構，營業收入亦隨之增加。110 年第一季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，此外，該公司及其子公司並透過優化客戶及產線組合，營業收入相較去年同期增加 23.58%。

與採樣同業相較，108 年度該公司及其子公司與採樣同業皆因中美貿易戰延續導致半導體產業呈現衰退趨勢，惟該公司及其子公司衰退幅度較採樣同業高，主係 108 年度該公司及其子公司因整體產能利用率偏低、記憶體市況不佳、單位售價(ASP)下跌所致。109 年度該公司及其子公司與採樣同業皆較去年同期呈現成長優勢，緣於中美貿易爭端趨緩和、以及 5G、車用電子及物聯網等新應用領域發展，致全球半導體市場自 108 年度之低迷逐漸復甦，其中力積電成長幅度大於採樣同業，主係記憶體產業自從谷底回升、受惠記憶體及邏輯報價同步上揚、及 108 年度相對同業基期較低所致。110 年第一季全球半導體產業延續 109 年的成長態勢，受惠於 5G、車用電子及物聯網、人工智慧等晶片需求，及新冠肺炎疫情帶動居家工作、遠距教學、伺服器等宅經濟相關資訊產品，該公司及其子公司與採樣同業之營業收入均呈現成長態勢。整體而言，該公司及其子公司與採樣同業營業收入變動均呈相同趨勢，尚無異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及 110 年第一季營業收入消長，主係隨著半導體產業市況、優化客戶及產線組合等因素而變化，其變動情形尚屬合理；與採樣同業趨勢相同，惟增減幅度互為優劣，尚無重大異常情事。

2.營業毛利

年度 公司	107 年度		108 年度		109 年度		110 年第一季	
	金額	毛利率(%)	金額	毛利率(%)	金額	毛利率(%)	金額	毛利率(%)
力積電	15,280,265	30.61	3,000,668	8.36	10,992,411	24.06	4,434,680	33.50
聯電	22,840,027	15.10	21,314,972	14.38	38,997,101	22.05	12,494,302	26.53
世界	10,168,270	35.15	10,332,787	36.53	11,256,284	33.97	3,497,817	38.10
華邦電	19,151,103	37.41	12,913,852	26.48	17,040,136	28.08	8,010,618	37.56

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之營業毛利分別為 15,280,265 仟元、3,000,668 仟元、10,992,411 仟元及 4,434,680 仟元，分別較去年同期變化為(80.36)%、266.33%及 53.94%，營業毛利主要隨營收規模增減而變動，毛利率分別為 30.61%、8.36%、24.06%及 33.50%。108 年度營業毛利較 107 年度減少 12,279,597 仟元，減少幅度 80.36%，主係半導體產業呈現衰退趨勢致整體訂單減少、單位售價(ASP)下跌，整體產能使用率下降，使得產品之單位成本上升，導致營業毛利及毛利率下降。109 年度營業毛利較 108 年度增加 7,991,743 仟元，成長幅度達 266.33%，主要受惠於終端市場的需求使訂單增加，產能利用率提升、單位售價(ASP)回升及持續推進製程技術所致。110 年第一季營業毛利較去年同期增加 1,553,926 仟元，成長幅度 53.94%，主係受惠產能利用率近滿載、持續推進製程技術以降低成本，及晶圓代工及記憶體漲價效應，持續推升毛利率所致。

與採樣同業相較，聯電旗下共有 7 座 8 吋廠以及 4 座 12 吋廠，主要從事成熟及特殊製程的晶圓製造，其中 109 年度毛利率大幅成長，主係受惠於終端市場需求增加，自 109 年第三季起接單暢旺且產能利用率近滿載，加上成功整合日本 USJC 12 吋業務，毛利率成長至 22.05%。世界主要擁有四座 8 吋廠以成熟製程為主，110 年度購入友達 L3B 廠成為旗下第 5 座晶圓廠，主要為生產 IGBT 等電源管理產品，因 8 吋晶圓廠主要設備已折舊完畢，使得固定成本較低，故最近三年度之毛利率介於 33.97%~36.53%，相較其他採樣同業為高。華邦電主要從事利基型記憶體 IC 設計、製造與銷售，108 年度因記憶體產業受總體經濟影響，庫存去化緩慢、市場需求不如預期，毛利率下降至 26.48%。109 年度毛利率微幅上升至 28.08%，主係受惠於 109 年度第四季記憶體毛利率上揚所致。110 年第一季因半導體需求增溫，各晶圓代工廠產能處於滿載水準，及由於三大記憶體廠商(三星、SK 海力士、美光)在 109 年下半年將舊製程利基型 DRAM 產能移轉至 CMOS 影像感測器製程後，使得 DRAM 市場供給產生短缺，在單位售價(ASP)及產能利用率提升之下，該公司及其子公司與採樣同業毛利率均呈同幅成長。

該公司及其子公司與採樣同業因銷售產品、銷售策略及生產模式不同，造成營業毛利率有所差異，其中除 108 年度因整體產能利用率偏低，致毛利率均低於採樣同業外，107、109 年度及 110 年第一季之營業毛利率均介於採樣同業之間。依上述分析營業毛利率之變動尚無發現重大異常情事。

3.營業(損)益

年度 公司	107 年度		108 年度		109 年度		110 年第一季	
	金額	營業利益率(%)	金額	營業利益率(%)	金額	營業利益率(%)	金額	營業利益率(%)
力積電	8,886,597	17.80	(2,098,779)	(5.85)	5,744,244	12.57	2,840,356	21.45
聯電	5,797,232	3.83	4,689,850	3.16	22,007,407	12.45	7,621,747	16.18
世界	7,154,708	24.73	6,909,389	24.43	7,416,206	22.38	2,450,890	26.70
華邦電	7,926,697	15.48	1,255,209	2.57	1,627,291	2.68	2,295,821	10.77

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告之財務報告。

項目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年第一季
推銷費用	461,925	300,790	335,218	108,006
管理費用	2,736,267	2,008,972	1,890,511	579,183
研究發展費用	3,453,483	2,962,370	3,234,765	927,399
營業費用	6,651,675	5,272,132	5,460,494	1,614,588
營業費用率(%)	13.33	14.69	11.95	12.20

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之營業費用分別為 6,651,675 仟元、5,272,132 仟元、5,460,494 仟元及 1,614,588 仟元，營業費用率分別為 13.33%、14.69%、11.95%及 12.20%；107~109 年度及 110 年第一季之營業(損)益分別為 8,886,597 仟元、(2,098,779)仟元、5,744,244 仟元及 2,840,356 仟元，營業(損)益率分別為 17.80%、(5.85)%、12.57%及 21.45%。

推銷費用主要係為業務人員之薪資及相關費用、園區管理費、間接材料及折舊費用等，108 年度推銷費用相較 107 年度減少 161,135 仟元，主要係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金及員工酬勞等帳列薪資費用減少 128,315 仟元，及園區管理費減少 29,359 仟元。109 年推銷費用增加 34,428 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 17,530 仟元且因營收成長致園區管理費增加 18,236 仟元所致。110 年第一季推銷費用相較去年同期增加 27,436 仟元，主係因業績成長，獎金及員工認股權帳列之薪資費用增加 11,621 仟元、員工酬勞估列數增加 8,541 仟元，及園區管理費增加 4,987 仟元所致。

管理費用主要係間接人員之薪資費用、折舊費用、環保費用、電腦使用費及專業服務費(勞務費)等，108 年度管理費用減少 727,295 仟元，主係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 107 年度減少 277,427 仟元，及員工酬勞減少 410,830 仟元。109 年度管理費用減少 118,461 仟元，主係竹南廠於 108 年 5 月前屬建廠期間，期間費用 318,118 仟元帳列管理費用，108 年 6 月起帳列製造費用，故 109 年管理費用減少。排除竹南廠建廠費用後，管理費用增加 199,657 仟元，主係獎金及員工酬勞增加。110 年第一季管理費用相較去年同期增加 157,244 仟元，主係員工酬勞估列數增加 132,109 仟元。

研究發展費用主要為研發人員之薪資費用、專業服務費、電腦使用費、製程及技術改善費用、折舊費用、光罩費用及間接材料等，108 年度研究發展費用減少 491,113 仟元，主係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 107 年度減少 516,765 仟元。109 年研究發展費用增加 272,395 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 288,095 仟元所致。110 年第一季研究發展費用相較去年同期增加 175,861 仟元，主係因業績成長而薪資費用、員工酬勞估列數分別增加 43,438 仟元及 70,069 仟元，與專業服務費、折舊費用及電腦使用費合計增加 86,885 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司營業費用變化，主係隨著該年度營收及稅前損益減少及增加，致間接人員之績效獎金、員工酬勞等薪資費用同幅增減變動所致。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 108 年度之營業利益率均低於所有採樣同業，107、109 年度及 110 年第一季則介於採樣同業之間。該公司及其子公司於 108 年度因整體產能利用率偏低，毛利率由 30.61%降至 8.36%，致營業利益率為負且低於採樣同業，而 109 年度主係邏輯 IC 出貨暢旺，且記憶體報價自谷底回溫及該公司及子公司持續產品組合優化致營收成長，且成本費用控管得宜，致 109 年度營業費用率下降至 11.95%，營業利益率成長至 12.57%，其營業利益率已與採樣同業聯電相近。110 年第一季隨著毛利率大幅上升至 33.50%，營業利益率隨之明顯增長至 21.45%，與採樣同業相較，其營業利益率超越聯電及華邦電，僅次於世界。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及 110 年第一季之營業利益率與採樣同業相較互有高低，主要係因各公司之營運模式、銷售產品及費用控管不盡相同，導致營業利益率亦有所差異，惟該公司及其子公司透過優化客戶及產線組合、推進製程技術、調升代工價格與產能利用率，使得營業利益率逐年成長，持續提升獲利能力，經評估應無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司最近三年度及 110 年第一季營業收入、營業毛利及營業利益之變化情形，尚無重大異常之情事。

(二)列表並說明最近期及最近三個會計年度以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

主要產品別銷貨收入變動表

單位：新臺幣仟元

年度 產品別	107 年度		108 年度		109 年度		110 年第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
邏輯暨特殊應用產品	21,590,848	43.26	16,703,015	46.53	25,657,228	56.16	7,569,254	57.17
記憶體產品（片）	16,337,034	32.73	10,809,807	30.11	14,049,468	30.75	3,564,689	26.93
記憶體產品（顆）	11,985,897	24.01	8,384,299	23.36	5,977,919	13.09	2,105,117	15.90
合計	49,913,779	100.00	35,897,121	100.00	45,684,615	100.00	13,239,060	100.00

主要產品別銷貨成本變動表

單位：新臺幣仟元

年度 產品別	107 年度		108 年度		109 年度		110 年第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
邏輯暨特殊應用產品	15,791,962	45.60	13,388,912	40.70	17,978,616	51.82	4,819,285	54.74
記憶體產品（片）	10,671,327	30.81	8,655,511	26.31	10,873,832	31.35	2,677,609	30.41
記憶體產品（顆）	8,170,225	23.59	10,852,030	32.99	5,839,756	16.83	1,307,486	14.85
合計	34,633,514	100.00	32,896,453	100.00	34,692,204	100	8,804,380	100

主要產品別銷貨毛利變動表

單位：新臺幣仟元

年度 產品別	107 年度		108 年度		109 年度		110 年第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
邏輯暨特殊應用產品	5,798,886	37.95	3,314,103	110.45	7,678,612	69.85	2,749,969	62.01
記憶體產品（片）	5,665,707	37.08	2,154,296	71.79	3,175,636	28.89	887,080	20.00
記憶體產品（顆）	3,815,672	24.97	(2,467,731)	(82.24)	138,163	1.26	797,631	17.99
合計	15,280,265	100.00	3,000,668	100.00	10,992,411	100.00	4,434,680	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司之主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，另由於記憶體單位區分為片及顆，故主要產品別分別為邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品(片)及記憶體產品(顆)。茲就該公司及其子公司主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形說明如下：

1.邏輯暨特殊應用產品

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季邏輯暨特殊應用產品之營業收入分別為 21,590,848 仟元、16,703,015 仟元、25,657,228 仟元及 7,569,254 仟元，占整體營業收入淨額之比率分別為 43.26%、46.53%、56.16%及 57.17%。108 年度邏輯暨特殊應用產品營業收入相較 107 年度減少 4,887,833 仟元，降低幅度為 22.64%，主係因國際間貿易緊張氛圍帶來不確定性，且消費型裝置如液晶電視、筆記型電腦、平板電腦、智慧手機和其他主要應用的顯示模組需求已達到飽和，終端客戶拉貨意願降低，致整體需求減少，且 108 年度平均單價相較 107 年度亦呈現下滑。109 年度邏輯暨特殊應用產品營業收入相較 108 年度增加 8,954,213 仟元，成長幅度達 53.61%，受惠於 5G 產業、車用市場及人工智慧等應用需求增加，為半導體產業注入成長動能，致該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺，營收隨之大幅成長。110 年第一季邏輯暨特殊應用產品營業收入相較去年同期增加 1,777,791 仟元，主係受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，

與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季邏輯暨特殊應用產品之營業成本分別為 15,791,962 仟元、13,388,912 仟元、17,978,616 仟元及 4,819,285 仟元，營業毛利分別為 5,798,886 仟元、3,314,103 仟元、7,678,612 仟元及 2,749,969 仟元，毛利率分別為 26.86%、19.84%、29.93%及 36.33%。108 年度營業毛利較 107 年度減少 2,484,783 仟元，變動比率為(42.85)%，毛利率由 26.86%下降至 19.84%，主係因邏輯暨特殊應用產品應用終端需求趨緩，訂單減少導致營業毛利及毛利率下降。109 年度營業毛利較 108 年度增加 4,364,509 仟元，變動比率為 131.70%，毛利率由 19.84%上升至 29.93%，主係受惠於半導體終端需求增長之效益，使訂單量增加、整體產能利用率提升，致營業成本下降，毛利率隨之上升。110 年第一季營業毛利較去年同期增加 929,222 仟元，變動比率為 51.04%，毛利率大幅上升至 36.33%，主係全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能利用率達滿載、且報價隨之上揚所致。

2.記憶體產品(片)

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季記憶體產品(片)之營業收入分別為 16,337,034 仟元、10,809,807 仟元、14,049,468 仟元及 3,564,689 仟元，占整體營業收入之比率分別為 32.73%、30.11%、30.75%及 26.93%。108 年度記憶體產品(片)營業收入相較 107 年度減少 5,527,227 仟元，降低幅度為 33.83%，主係 107 年底客戶端與記憶體供應商的庫存水位皆達到相對高點，且 108 年度受到美中貿易戰造成供應鏈趨於保守，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱，致記憶體價格及銷售量在 108 年上半年度快速滑落。109 年度記憶體產品(片)營業收入相較去年同期增加 3,239,661 仟元，變動幅度為 29.97%，主係由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，其中 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，且由於三大記憶體廠商(三星、SK 海力士、美光)在 109 年下半年將舊製程 DRAM 產能移轉至 CMOS 影像感測器製程後，使得 DRAM 市場供給產生短缺，帶動需求增加所致。110 年第一季記憶體產品(片)營業收入相較去年同期減少 70,691 仟元，變動幅度為 1.94%，變動幅度尚不重大。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季記憶體產品(片)之營業成本分別為 10,671,327 仟元、8,655,511 仟元、10,873,832 仟元及 2,677,609 仟元，營業毛利分別為 5,665,707 仟元、2,154,296 仟元、3,175,636 仟元及 887,080 仟元，毛利率分別為 34.68%、19.93%、22.60%及 24.89%，108 年度營業毛利較 107 年度減少 3,511,411 仟元，變動比率為(61.98)%，毛利率下降至 19.93%，主係因記憶體市場需求疲軟，處於供過於求的狀態，故該公司及其子公司訂單量減少、整體產能使用率大幅降低所致。109 年度營業毛利較 108 年度增加 1,021,340 仟元，變動比率為 47.41%，主係由於 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，使訂單量增加、整體產能利用率提升，致營業成本下降，毛利率成長至 22.60%。110 年第一季除承接 109 年度產業整體態勢外，且單位報價持續上揚，毛利率更進而成長至 24.89%。

3.記憶體產品(顆)

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季記憶體產品(顆)之營業收入分別為 11,985,897 仟元、8,384,299 仟元、5,977,919 仟元及 2,105,117 仟元，占整體營業收入之比率分別為 24.01%、23.36%、13.09%及 15.90%，主係為 PC DRAM 及包裝元件等。108 年度記憶體產品(顆)之營業收入較 107 年度減少 3,601,598 仟元，變動比率(30.05)%，主係 108 年度因智慧型手機成長趨緩、終端需求降溫等因素，出現供過於求的狀況，致平均銷售價格(ASP)下跌。109 年度由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，致記憶體市況雖至谷底回溫，惟 PC 應用相關成長力道相對持平，且該公司及其子公司為逐漸降低記憶體價格波動過大產生之營運風險，108 年度開始改變銷售產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，故記憶體銷售數量相較前一年度略為降低，致 109 年度記憶體產品(顆)營業收入占整體營業收入比率降至 13.09%。110 年第一季記憶體產品(顆)之營業收入相較去年同期增加 819,384 仟元，變動比率為 63.73%，主係標準型 DRAM 受惠於新冠肺炎疫情持續推動筆電出貨動能所致。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季記憶體產品(顆)之營業成本分別為 8,170,225 仟元、10,852,030 仟元、5,839,756 仟元及 1,307,486 仟元，營業毛利分別為 3,815,672 仟元、(2,467,731)仟元、138,163 仟元及 797,631 仟元，毛利率分別為 31.83%、(29.43)%、2.31%及 37.89%，108 年度營業毛利較 107 年度大幅減少 6,283,403 仟元，毛利率下降至(29.43)%，主係因記憶體市場需求疲軟，處於供過於求的狀態，故該公司及其子公司訂單量減少、整體產能使用率大幅降低所致，此外，記憶體產品(顆)主要應用之 PC DRAM 終端報價跌幅甚鉅，故毛利率呈現負數。109 年度營業毛利較 108 年度增加 2,605,894 仟元，毛利率為 2.31%，雖銷售金額相較去年度下滑，惟整體產能利用率提升，致營業成本下降，毛利率由負轉為正。110 年第一季受惠終端需求增溫、產能利用率滿載，且單位報價持續上揚，毛利率大幅成長至 37.89%。

綜上所述，107~109 年度及 110 年第一季主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化趨勢，尚無重大異常之情事。

(三)最近期及最近三個會計年度營業收入或毛利率變動達百分之二十以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度之營業收入及毛利率變動率如下表所示：

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	107 年度	108 年度		109 年度		109 年第一季	110 年第一季	
	金額	金額	變動率	金額	變動率	金額	金額	變動率
營業收入	49,913,779	35,897,121	(28.08)	45,684,615	27.27	10,712,576	13,239,060	23.58
營業毛利	15,280,265	3,000,668	(80.36)	10,992,411	266.33	2,880,754	4,434,680	53.94
毛利率(%)	30.61	8.36	(72.69)	24.06	187.80	26.89	33.50	24.58

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

依上表所示，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之營業收入及毛利率變動率均達 20%以上，故應進行價量分析。茲將主要產品邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品(片)及記憶體產品(顆)之價量變動情形及合理性分析說明如下：

單位：新臺幣仟元

主要產品	分析項目	107 及 108 年度	108 及 109 年度	109 年第一季及 110 年第一季
邏輯暨特殊應用產品	(一)營業收入差異分析：			
	P(Q'−Q)	(4,140,766)	9,687,758	1,269,149
	Q(P'−P)	(924,340)	(464,269)	417,213
	(P'−P)(Q'−Q)	177,273	(269,276)	91,429
	P'Q'−PQ	(4,887,833)	8,954,213	1,777,791
	(二)營業成本差異分析：			
	P(Q'−Q)	(3,028,636)	7,765,576	870,148
	Q(P'−P)	774,032	(2,010,045)	(17,700)
	(P'−P)(Q'−Q)	(148,446)	(1,165,827)	(3,879)
	P'Q'−PQ	(2,403,050)	4,589,704	848,569
	(三)毛利變動金額：	(2,484,783)	4,364,509	929,222
記憶體產品(片)	(一)營業收入差異分析：			
	P(Q'−Q)	(4,002,004)	4,149,881	(444,421)
	Q(P'−P)	(2,020,070)	(657,721)	425,782
	(P'−P)(Q'−Q)	494,847	(252,499)	(52,052)
	P'Q'−PQ	(5,527,227)	3,239,661	(70,691)
	(二)營業成本差異分析：			
	P(Q'−Q)	(2,614,103)	3,322,848	(327,438)
	Q(P'−P)	792,397	(798,127)	372,079
	(P'−P)(Q'−Q)	(194,110)	(306,400)	(45,486)
	P'Q'−PQ	(2,015,816)	2,218,321	(845)
	(三)毛利變動金額：	(3,511,411)	1,021,340	(69,846)
記憶體產品(顆)	(一)營業收入差異分析：			
	P(Q'−Q)	3,542,855	(2,461,751)	99,041
	Q(P'−P)	(5,514,460)	78,386	668,823
	(P'−P)(Q'−Q)	(1,629,993)	(23,015)	51,520
	P'Q'−PQ	(3,601,598)	(2,406,380)	819,384
	(二)營業成本差異分析：			
	P(Q'−Q)	2,414,999	(3,186,312)	91,101
	Q(P'−P)	205,935	(2,584,936)	31,320
	(P'−P)(Q'−Q)	60,871	758,974	2,413
	P'Q'−PQ	2,681,805	(5,012,274)	124,834
	(三)毛利變動金額：	(6,283,403)	2,605,894	694,550
毛利變動金額合計數		(12,279,597)	7,991,743	1,553,926

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：單位係為換算 12 吋約當片。

註 2：P'、Q'為本期之單價及數量；P、Q 為前期之單價及數量

1.邏輯暨特殊應用產品

(1)107 及 108 年度

A.營業收入減少 4,887,833 仟元

108 年度主係因國際間貿易緊張氛圍帶來不確定性，且消費型裝置如液晶電視、筆記型電腦、平板電腦、智慧手機和其他主要應用的顯示模組需求已達到飽和，終端客戶拉貨意願降低致整體需求減少，且 108 年度平均單價相較 107 年度亦呈現下滑，故產生數量不利差異 4,140,766 仟元及價格不利差異 924,340 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 177,273 仟元。

B.營業成本減少 2,403,050 仟元

108 年度主係因邏輯暨特殊應用產品應用終端需求趨緩，因銷售量下降，產生數量有利差異 3,028,636 仟元；108 年度因當年度整體產能利用率下降，使單位成本上升，產生價格不利差異 774,032 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 148,446 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 108 年度邏輯暨特殊應用產品之營業毛利較 107 年度減少 2,484,783 仟元。

(2)108 及 109 年度

A.營業收入增加 8,954,213 仟元

109 年度受惠於 5G 產業、車用市場及人工智慧等應用需求增加，為半導體產業注入成長動能，致該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺，故產生數量有利差異 9,687,758 仟元；109 年度邏輯暨特殊應用產品市況雖相較於 108 年度已逐漸回溫，惟消費性電子及面板等終端應用方面，於上半年度仍受到經濟不確定性風險因素之影響，且受美金匯率報價影響，致全年度平均售價仍微幅低於 108 年度，產生價格不利差異 464,269 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 269,276 仟元。

B.營業成本增加 4,589,704 仟元

109 年度主係受惠於半導體終端需求增長之效益，使邏輯暨特殊應用產品訂單量增加，產生數量不利差異 7,765,576 仟元；此外，隨訂單量增加致整體產能利用率提高，使單位成本下降，產生價格有利差異 2,010,045 仟元，銷售量增加且單位成本下降之情況下，銷貨成本產生有利組合差異 1,165,827 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 109 年度邏輯暨特殊應用產品之營業毛利較 108 年度增加 4,364,509 仟元。

(3)110 年第一季及 109 年第一季

A.營業收入增加 1,777,791 仟元

110 年第一季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能利用率達滿載、且報價隨之上揚，公司調整生產產品組合產生數量有利差異 1,269,149 仟元；報價隨上揚產生價格有利差異 417,213 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 91,429 仟元。

B.營業成本增加 848,569 仟元

110 年第一季受惠於半導體產業持續熱絡，全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能利用率達滿載，銷售數量增加產生成本數量不利差異 870,148 仟元；單位成本減少產生價格有利差異 17,700 仟元，銷貨成本產生有利組合差異 3,879 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 110 年第一季邏輯暨特殊應用產品之營業毛利較 109 年第一季增加 929,222 仟元。

2.記憶體產品(片)

(1)107 及 108 年度

A.營業收入減少 5,527,227 仟元

108 年度記憶體產品(片)營業收入減少，主係 107 年底客戶端與記憶體供應商的庫存水位皆達到相對高點，且受到美中貿易戰造成供應鏈趨於保守，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱，是以在 108 年度終端庫存水位較高、採購動能轉弱、整體供過於求情況下，導致記憶體價格及銷售量在 108 年上半年度快速滑落，故產生數量不利差異 4,002,004 仟元及價格不利差異 2,020,070 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 494,847 仟元。

B.營業成本減少 2,015,816 仟元

108 年度因記憶體市場需求疲軟，致銷售數量減少，產生數量有利差異 2,614,103 仟元，及因當年度整體產能利用率下降，使單位成本上升，產生價格不利差異 792,397 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 194,110 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 108 年度記憶體產品(片)之營業毛利較 107 年度減少 3,511,411 仟元。

(2)108 及 109 年度

A.營業收入增加 3,239,661 仟元

109 年度主係由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，其中 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，故記憶體產品(片)銷售數量相較 108 年度增加，產生數量有利差異 4,149,881 仟元，而記憶體報價雖於 109 年度第四季至谷底回升，惟受到美金報價匯率下跌之不利影響，故產生價格不利差異 657,721 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 252,499 仟元。

B.營業成本增加 2,218,321 仟元

109 年度因記憶體銷售數量相較前一年度增加，產生數量不利差異 3,322,848 仟元，此外，該公司及其子公司 109 年度整體產能利用率提高，使單位成本下降，價格有利差異 798,127 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 306,400 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 109 年度記憶體產品(片)之營業毛利較 108 年度增加 1,021,340 仟元。

(3)110 年第一季及 109 年第一季

A.營業收入減少 70,691 仟元

110 年第一季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能持續滿載，所以公司調整生產產品組合，記憶體產品(片)銷售數量相較 109 年第一季減少，產生數量不利差異 444,421 仟元，而記憶體報價持續上揚故產生價格有利差異 425,782 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 52,052 仟元。

B.營業成本減少 845 仟元

110 年第一季因記憶體銷售數量相較去年同期減少，產生數量有利差異 327,438 仟元，單位成本上升產生價格不利差異 372,079 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 45,486 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 110 年第一季記憶體產品(片)之營業毛利較 109 年第一季減少 69,846 仟元。

3.記憶體產品(顆)

(1)107 及 108 年度

A.營業收入減少 3,601,598 仟元

108 年度記憶體產品(顆)營業銷售價格下降，主係 107 年底客戶端與記憶體供應商的庫存水位皆達到相對高點，且受到美中貿易戰造成供應鏈趨於保守，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱，導致記憶體價格快速滑落，產生價格不利差異 5,514,460 仟元；在 108 年度 DRAM 價格相對較低，許多 DRAM 模組廠營收也隨之下滑，惟該公司及其子公司之主要銷售客戶 H 公司居於 DRAM 模組供應商的領導地位，是少數逆勢成長的公司，向該公司及其子公司採購數量相較去年同期增加，故產生數量有利差異 3,542,855 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 1,629,993 仟元。

B.營業成本增加 2,681,805 仟元

108 年度因主要銷售客戶 H 公司，致銷售數量增加，產生數量不利差異 2,414,999 仟元，及因當年度整體產能利用率下降，使單位成本上升，產生價格不利差異 205,935 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 60,871 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 108 年度記憶體產品之營業毛利較 107 年度減少 6,283,403 仟元。

(2)108 及 109 年度

A.營業收入減少 2,406,380 仟元

109 年度由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，致記憶體市況雖至谷底回溫，惟 PC 應用相關成長力道相對持平，且該公司及其子公司為逐漸降低記憶體價格波動過大產生之營運風險，108 年度開始改變銷售產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，故記憶體銷售數量相較前一年度略為降低，產生數量不利差異 2,461,751 仟元，而記憶體報價於 109 年度第四季至谷底回升，故產生價格有利差異 78,386 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 23,015 仟元。

B.營業成本減少 5,012,274 仟元

109 年度因記憶體銷售數量相較前一年度略為降低，產生數量有利差異 3,186,312 仟元，此外，該公司及其子公司 109 年度整體產能利用率提高，使單位成本下降，價格有利差異 2,584,936 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 758,974 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 109 年度記憶體產品(顆)之營業毛利較 108 年度增加 2,605,894 仟元。

(3)110 年第一季及 109 年第一季

A.營業收入增加 819,384 仟元

110 年第一季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能持續滿載，所以公司調整生產產品組合，記憶體產品(顆)銷售數量相較 109 年第一季增加，產生數量有利差異 99,041 仟元，而記憶體報價持續上揚故產生價格有利差異 668,823 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 51,520 仟元。

B.營業成本增加 124,834 仟元

110 年第一季因記憶體銷售數量相較前期增加，產生數量不利差異 91,101 仟元，單位成本增加產生價格不利差異 31,320 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 2,413 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 110 年第一季記憶體產品(顆)之營業毛利較 109 年第一季增加 694,550 仟元。

經評估該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之主要產品別之營業收入、營業成本與營業毛利之變化情形，及其價量變化情形，尚屬合理，應無重大異常情事。

肆、財務狀況

一、列表並說明最近期及最近三個會計年度財務比率之分析，與同類別上市公司及未上市同業財務比率之比較分析，應包括財務結構、償債能力、經營能力及獲利能力

(一)選擇採樣公司之理由

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工(顯示驅動 IC 產品、電源管理晶片產品、分離式元件產品、CMOS 影像感測器產品、嵌入式非揮發記憶體產品之晶圓代工服務)；以及記憶體產品晶圓代工(動態隨機存取記憶體產品、快閃記憶體產品之晶圓代工服務)。

經檢視其相關產業及同業資料，上市公司聯電以 12 吋晶圓代工服務及 8 吋晶圓代工服務為主；上櫃公司世界係 8 吋晶圓代工服務為主；上市公司華邦電主要以 12 吋晶圓廠產製動態隨機存取記憶體及快閃記憶體產品，另透過其子公司新唐科技，提供 6 吋晶圓代工服務。經綜合考量國內上市及上櫃公司之營業項目、產業特性及資本額等因素，選取聯電、世界及華邦電做為採樣公司。

此外，參考財團法人金融聯合徵信中心編印之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」中所列「C26 電子零組件製造業」之財務比率作為同業平均之財務比率依據。

公司名稱	代號	主要營業項目	產能	銷售比重
力積電	6770	提供半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工以及記憶體產品晶圓代工。	109 年產能： 8 吋廠 2 座：900 仟片 12 吋廠 3 座：1,260 仟片	109 年度：56%邏輯產品；44%記憶體產品
聯　電	2303	積體電路各種半導體相關零組件。	109 年產能： 6 吋廠 1 座：371 仟片。 8 吋廠 7 座：3,853 仟片。 12 吋廠 4 座:2,281 仟片。	100%邏輯產品
世　界	5347	依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。 提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。 提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。	109 年產能： 8 吋廠 4 座，3 座於臺灣，1 座於新加坡：約 2,900 仟片。	100%邏輯產品
華邦電	2344	積體電路；半導體記憶零組件及其系統產品；電腦系統用、數位通訊用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品；其他半導體零組件；電腦軟體程式設計及資料處理；兼營與業務相關之進出口貿易業務。	109 年度年產能： 12 吋(記憶體)：666 仟片 6 吋(邏輯)：692 仟片	109 年度：66%記憶體產品；34%邏輯產品。

資料來源：公開資訊觀測站、各公司年報，各公司網站、法說會簡報資料。

(二)最近期及最近三個會計年度財務比率與同類別上市、上櫃公司及未上市、上櫃同業財務比率之比較分析

單位：%；次；每股元

評估項目		年度 公司	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至 3 月 31 日
財務結構	負債占資產比率(%)	力積電	55.78	59.29	57.91	58.52
		聯　電	43.35	44.02	37.55	36.67
		世　界	21.81	30.99	32.32	32.82
		華邦電	33.48	39.07	43.99	42.58
		同　業	44.5	45.4	註 4	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	力積電	120.23	121.44	129.77	137.27
		聯　電	182.07	197.82	225.40	249.73
		世　界	472.74	236.34	238.59	249.73
		華邦電	151.61	153.20	163.65	171.02
		同　業	209.21	187.62	註 4	
償債能力	流動比率(%)	力積電	119.47	112.22	123.19	140.95
		聯　電	282.96	211.45	209.99	228.04
		世　界	358.91	190.60	194.35	217.85
		華邦電	227.86	214.42	186.58	201.98
		同　業	172.4	163.20	註 4	
	速動比率(%)	力積電	79.32	67.79	76.71	93.42
		聯　電	223.98	172.94	178.20	196.68
		世　界	309.13	160.81	165.96	188.41
		華邦電	161.63	155.43	131.07	144.50
		同　業	135.90	130.70	註 4	
	利息保障倍數(倍)	力積電	17.36	(3.51)	7.65	13.79
		聯　電	1.79	2.96	14.93	29.27
		世　界	0.00	179.74	114.75	206.41
		華邦電	33.46	5.36	4.47	18.15
		同　業	1,339.4	940.70	註 4	
經營能力	應收款項週轉率(次)(註 2)	力積電	8.50	6.10	7.86	7.80
		聯　電	6.59	5.89	6.56	6.62
		世　界	5.90	5.29	6.19	6.11
		華邦電	7.55	7.53	7.43	8.07
		同　業	4.90	5.00	註 4	
	應收款項週轉天數(日)	力積電	43	60	47	47
		聯　電	56	62	56	56
		世　界	62	69	59	60
		華邦電	49	49	50	46
		同　業	75	註 4	註 4	
	存貨週轉率(次)(註 2)	力積電	5.39	5.01	4.88	4.52
		聯　電	7.04	6.36	6.23	6.18
		世　界	6.05	5.50	7.08	7.08
		華邦電	3.36	3.38	3.57	3.72
		同　業	7.20	7.10	註 4	
	存貨週轉天數(日)	力積電	68	73	75	81
		聯　電	52	58	59	60
		世　界	61	67	52	52
		華邦電	109	109	103	99
		同　業	51	51	註 4	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	力積電	1.32	0.82	0.97	1.13
		聯　電	0.80	0.92	1.25	1.45
		世　界	4.56	2.85	2.46	2.65
		華邦電	1.06	0.89	1.02	1.40

評估項目		年度 公司	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至 3 月 31 日
		同　業	3.10	2.70	註 4	
	總資產週轉率(次)	力積電	0.81	0.51	0.60	0.66
		聯　電	0.40	0.40	0.47	0.49
		世　界	0.80	0.70	0.77	0.81
		華邦電	0.56	0.49	0.53	0.67
		同　業	0.90	0.90	註 4	
獲利能力	權益報酬率(%)	力積電	23.37	(8.83)	12.07	25.10
		聯　電	1.26	2.96	12.27	16.30
		世　界	21.52	19.88	21.34	28.81
		華邦電	12.31	2.31	2.26	9.49
		同　業	1.70	1.60	註 4	
	營業利益占實收資本額比率(%)	力積電	247.77	(6.76)	18.50	36.59
		聯　電	4.67	3.99	17.72	24.54
		世　界	43.65	42.16	45.25	59.81
		華邦電	19.92	3.15	4.09	23.07
		同　業	註 1	註 1	註 1	
	稅前純益占實收資本額比率(%)	力積電	240.89	(8.42)	15.45	33.13
		聯　電	1.76	4.88	22.48	35.37
		世　界	45.59	44.90	46.17	61.34
		華邦電	21.09	4.40	4.55	22.05
		同　業	註 1	註 1	註 1	
	純益率(%)	力積電	13.85	(7.36)	8.33	15.92
		聯　電	1.75	4.14	15.37	21.00
		世　界	21.32	20.72	19.03	24.11
		華邦電	15.10	3.03	2.50	8.01
		同　業	8.10	6.40	註 4	
	每股稅後盈餘(元)(註 3)	力積電	2.56	(0.94)	1.23	0.68
		聯　電	0.58	0.82	2.42	0.85
		世　界	3.76	3.58	3.85	1.35
		華邦電	1.87	0.32	0.33	0.40
		同　業	註 1	註 1	註 1	
現金流量	現金流量比率(%)	力積電	68.88	13.02	54.64	13.18
		聯　電	102.08	75.51	84.03	23.28
		世　界	103.77	76.23	94.15	38.79
		華邦電	82.17	60.38	43.64	13.17
		同　業	20.00	25.70	註 4	
	現金流量允當比率(%)(註 5)	力積電	84.14	54.31	75.83	78.71
		聯　電	79.96	90.89	107.04	152.02
		世　界	83.75	71.36	69.99	71.58
		華邦電	75.08	73.09	75.77	70.90
		同　業	註 1	註 1	註 1	
	現金再投資比率(%)	力積電	3.49	0.73	3.27	0.84
		聯　電	4.02	4.49	5.07	1.62
		世　界	2.51	3.07	5.12	4.18
		華邦電	5.20	3.31	3.67	1.14
		同　業	5.50	6.70	註 4	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率。

註 1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率、每股稅後盈餘及現金流量允當比率。

註 2：應收帳款週轉率係以總額計算；存貨週轉率係以淨額計算。

註 3：每股稅後盈餘係以基本每股盈餘作揭露。

註 4：財團法人金融聯合徵信中心尚未出版該年度之主要行業財務比率。

註 5：該公司及其子公司提供。
註 6：財務分析之計算公式如下
1.財務結構
(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝(股東權益＋非流動負債)／不動產、廠房及設備淨額
2.償債能力
(1)流動比率＝流動資產／流動負債
(2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付款項)／流動負債
(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前損益／本期利息支出
3.經營能力
(1)應收款項週轉率＝銷貨淨額／平均應收款項總額
(2)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨總額
(3)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額
(4)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額
4.獲利能力
(1)權益報酬率＝稅後純益／平均權益總額
(2)營業利益占實收資本額比率＝營業利益／期末實收資本額
(3)稅前純益占實收資本額比率＝稅前純益／期末實收資本額
(4)純益率＝稅後純益／銷貨淨額
(5)每股盈餘＝(歸屬於母公司業主之損益－特別股股利)／加權平均已發行股數
5.現金流量
(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債
(2)現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)
(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其它非流動資產＋營運資金)

(三)財務比率分析及與同業之比較分析說明如下

1.財務結構

(1)負債占資產比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之負債占資產比率分別為 55.78%、59.29%、57.91%及 58.52%，主係該公司及其子公司基於營運策略考量，於 106 年購入竹南廠及生產設備以擴充產線，並向銀行申請聯貸案，使得負債比率整體偏高；108 年度負債占資產比率較 107 年度上升，主係竹南廠進行第二階段擴建專案，向銀行申請聯貸案所致；109 年度負債占資產比率下降，係因該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營運資金增加所致；110 年第一季負債占資產比率較 110 年度略微上升，主係該公司及其子公司為營運需求，向銀行增加借款所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季負債占資產比率高於採樣公司及同業平均。晶圓製造是一個高資本投入的行業，每年都會有資本支出計畫，可能是在維護設備運作、既有產能去瓶頸化投資、或是建新廠，每家公司的產能建置狀況不同，所以每年度的不動產、廠房及設備投資金額也會有所差異，若是有新建廠的情形，通常需新舉債或耗用大筆自有資金，會使得負債比或流動比率變差。基本上可以取得不動產、廠房及設備金額與折舊費用的比例來判斷公司是否有新建廠或重大資本支出，若是比率低於 1，代表取得金額小於折舊費用，則代表該公司沒有積極擴增產能，反之，則可能有大規模投資。該公司及其子公司最近三年度及最近期取得不動產、廠房及設備金額與折舊費用的比例分別為 2.65、2.51、0.56 及 1.18 倍，除 109 年度低於 1 以

外，其他年度皆高於 1，顯見該公司持續擴大營運，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，故該等比率較差。相較於同業，聯電的比率皆低於 1，華邦電及世界分別於 107 及 108 年度高於 2，其餘各其皆低於 2，顯見該公司及其子公司擴產態度較為積極。惟隨該公司於 110 年第一季辦理第一次現金增資，於 110 年 6 月 11 日收足股款，並訂為現金增資基準日，預計至第二季財報負債比率將可隨之下降，尚無重大異常之情事。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 120.23%、121.44%、129.77%及 137.27%，108 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因擴建竹南廠增加長期銀行借款及租賃土地適用 IFRS 16 使用權資產之會計處理，租賃負債增加等使長期資金增加所致；109 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、盈餘獲利使淨值提升所致；110 年第一季長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長、盈餘獲利使淨值提升，且該公司及其子公司為營運需求，向銀行增加借款所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，由於該公司及其子公司積極擴建產能，不動產、廠房及設備金額自 108 年躍升為 474 億元後，持續維持在 470 多億或近 470 億元，再加上未來銅鑼 P5 的建廠計畫，未來會隨著驗收進度，持續增加不動產、廠房及設備金額。107~109 年度及 110 年第一季長期資金占不動產、廠房及設備比率雖低於採樣公司及同業平均，惟該等比率大於 100%，顯示該公司及其子公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，且已逐年改善，最近期已達 137.27%，與華邦電的 171.02%接近，110 年 6 月已完成總籌資金額 120 億元的增資案，再加上未來上市前現增可募集金額，將可大幅提高該比率，拉近與同業間的距離，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司及其子公司最近三年度及最近期之財務結構在營業規模逐漸成長及獲利挹注之下尚屬穩定，經評估應無重大異常之情事。

2.償債能力

(1)流動比率及速動比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之流動比率分別為 119.47%、112.22%、123.19%及 140.95%，速動比率分別為 79.32%、67.79%、76.71 %及 93.42%，速動比率與流動比率變動趨勢相似，其 108 年度流動比率及速動比率較 107 年度低，主係該公司及其子公司於 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低

檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入較 107 年度下降 28.08%，帳上現金及應收帳款下降，使得流動資產及速動資產減少；109 年度流動比率及速動比率較 108 年度高，係因該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，再加上當年度的資本支出規模較低，使得營業活動淨現金流入已足以支應投資活動及籌資活動的淨現金流出，故使流動資產項目中現金、應收帳款及存貨等皆較 108 年度增加所致；110 年第一季流動比率及速動比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營業收入增加，盈餘獲利使得營業活動淨現金流入，且該公司及其子公司為營運需求，向銀行增加借款，綜上所述，帳上現金增加及應收帳款增加，使得流動資產及速動資產增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，107~109 年度及 110 年第一季該公司及子公司流動比率及速動比率雖低於採樣公司及同業平均，惟流動比率大於 100%，顯示該公司及其子公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，且該公司及其子公司的流動比率及速動比率除了 108 年度因為虧損使得該比率較前一年度下滑外，隨著營運狀況越來越好，比率已逐步提升。由於該公司當初受讓力晶公司 12 吋晶圓製造相關營業資產與負債，連帶亦承接當初銀行團的聯貸契約，所以仍有部分歷史包袱需要再還，隨著業績狀況轉佳，公司已一步一步調整好財務體質，相關比率也越來越好。與採樣公司及同業平均水準相較，107~109 年度及 110 年第一季該公司及子公司流動比率及速動比率雖低於採樣公司及同業平均，惟流動比率大於 100%，顯示該公司及其子公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，且該等比率 109 年隨營收成長逐步提升，顯見其償債能力尚屬穩健，經評估其流動比率之變化應無重大異常情事。

(2)利息保障倍數

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之利息保障倍數分別為 17.36 倍、(3.51)倍、7.65 倍及 13.79 倍，108 年度利息保障倍數較 107 年低且為負數，主係該公司及其子公司於 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，當年度營業收入相較 107 年度下降，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度利息保障倍數增加，係因該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利所致；110 年第一季利息保障倍數增加，係因半導體需求熱絡，該公司及其子公司產品銷售價格上升、銷售數量增加，營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，108 年度由於該公司虧損，故保障倍數為負值，低於採樣公司及同業平均水準，不過華邦電及同業平均水準之利息保障倍數亦較 107 年度下滑，實為整體產業趨勢，主係因 108 年受貿易紛爭干擾，全球

經濟成長疲弱，消費市場需求不振，導致記憶體價格下跌，該公司及其子公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，受到記憶體價格下跌影響較鉅，且該公司及其子公司驅動 IC 產品新舊技術平台轉換，綜上所述造成 108 年度產生虧損，而使得利息保障倍數低；107、109 年度利息保障倍數均介於採樣公司及同業間；110 年第一季利息保障倍數與華邦電相當。整體而言，該公司及其子公司之償債能力尚屬無虞，與同業相較尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及最近期之償債能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

3.經營能力

(1)應收款項週轉率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之應收款項週轉率分別為 8.50 次、6.10 次、7.86 次及 7.80 次，108 年度應收帳款週轉率下降，主係 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降 28.08%，營業收入減少幅度高於平均應收款項總額減少幅度之故；109 年應收款項週轉率上升，係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致；110 年第一季應收款項週轉率略為下降，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長使期末應收帳款增加，使平均應收帳款較 109 年度增加所致。整體而言，該公司及其子公司之往來客戶多為國內外知名大廠，營運規模、財務狀況及長期往來信用良好，帳款品質穩定，且最近三年度及最近期並無實際發生呆帳損失，並無重大異常情事。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司 107 及 109 年度應收款項週轉率均優於採樣同業，108 年度及 110 年第一季應收款項週轉率及收現天數均介於採樣同業之間，採樣同業間應收款項週轉情形差異主係因各公司之營運規模、收款政策及客戶組成不同所致，應無重大異常之情事。

(2)存貨週轉率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之存貨週轉率分別為 5.39 次、5.01 次、4.88 次及 4.52 次，該公司及其子公司係以接單式生產及計畫性生產兼具之生產方式安排生產排程及採購作業，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，存貨週轉率主要受到因訂單排程及客製化產品須提前備料，因而略有增減。108 年度存貨週轉率較 107 年度下降，主係 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降，使相對的銷貨成本減少所致；而 109 年度存貨週轉率下降，則主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，109 年底為因應 110 年度訂單需

求故增加原料備貨，109 年存貨淨額提升所致；110 年第一季存貨週轉率略為下降，係因半導體需求熱絡，為因應訂單需求故持續增加原料備貨，使平均存貨較 109 年度平均存貨增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之存貨週轉率介於採樣公司及同業平均水準間，整體而言尚無重大異常情事。

(3)不動產、廠房及設備週轉率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 1.32 次、0.82 次、0.97 次及 1.13 次，108 年度不動產、廠房及設備週轉率較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 107 年增加所致；109 年度不動產、廠房及設備週轉率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均不動產、廠房及設備之幅度所致；110 年第一季不動產、廠房及設備週轉率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司 107 年度不動產、廠房及設備週轉率介於採樣公司及同業平均，108 年度華邦電及同業平均水準之不動產、廠房及設備週轉率亦較 107 年度下滑，惟該公司及其子公司不動產、廠房及設備週轉率皆低於採樣公司及同業平均水準，主係中美貿易影響半導體產業之不確定性因素繼續蔓延，邏輯產品終端客戶拉貨需求降低，加上記憶體市況不佳、單位售價(ASP)下跌等因素影響，致當年度營業收入相較 107 年度下降 28.08%，下滑幅度大於同業，而使得不動產、廠房及設備週轉率低；109 年度不動產、廠房及設備週轉率皆低於採樣公司及同業平均水準，惟在營運持續暢旺下，該公司及其子公司於 109 年度不動產、廠房及設備週轉率逐漸提升；110 年第一季不動產、廠房及設備週轉率介於採樣公司及同業平均。整體而言，該公司及其子公司產品別與華邦電相似，同時具有邏輯產品及記憶體產品，使得 108~109 年度及 110 年第一季不動產、廠房及設備週轉率與華邦電相當，尚無重大異常之情事。

(4)總資產週轉率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之總資產週轉率分別為 0.81 次、0.51 次、0.60 次及 0.66 次。108 年度總資產週轉率皆較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願致營業收入減少，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 107

年增加；109 年度因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均總資產之幅度所致；110 年第一季總資產週轉率上升，係因半導體需求熱絡，該公司及其子公司產品銷售價格上升、銷售數量增加，營收成長成長所致。與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司總資產週轉率 107~109 年度及 110 年第一季皆介於採樣公司及同業平均，尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司之經營能力各項指標尚屬穩健，經評估尚無重大異常之情事。

4.獲利能力

(1)權益報酬率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之權益報酬率分別為 23.37%、(8.83)%、12.07%及 25.10%，108 年度股東權益報酬較 107 年度低且為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少且公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故權益報酬率由負轉正；110 年第一季權益報酬率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司權益報酬率 107 年度高於採樣公司及同業平均，108 年度華邦電及同業平均水準之權益報酬率亦較 107 年度下滑，惟該公司及其子公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司及其子公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司及其子公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；109 年度及 110 年第一季介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈權益報酬率逐漸上升，顯示該公司及其子公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

(2)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之營業利益占實收資本額比率分別為 247.77%、(6.76)%、18.50%及 36.59%；稅前純益占實收資本額比率分別為 240.89%、(8.42)%、15.45%及 33.13%，107 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率較高，係因該公司及其子公司於 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組，收購力晶科技股份有限公司(以下簡稱力晶

科)12 吋晶圓廠相關資產負債，並發行新股予力晶科作為取得對價，此交易係屬於共同控制下的組織重組，應追溯視為自始合併並重編比較期間之合併報告，於 107 年度業經重編後的營業淨利及稅前純益係涵蓋受讓業務，然 107 年度實收資本額則未改變仍為未併購前金額，致使該比率有較大差異；108 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率皆由負轉正；110 年第一季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率，107 年度高於採樣公司及同業平均，108 年度華邦電之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率亦較 107 年度下滑，惟該公司及其子公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司及其子公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司及其子公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；109 年度及 110 年第一季介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司及其子公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

(3)純益率及每股稅後盈餘

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之純益率分別為 13.85%、(7.36)%、8.33%及 15.92%；每股稅後盈餘分別為 2.56、(0.94)、1.23 及 0.68，108 年度純益率及每股稅後盈餘較 107 年度低且為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，致 108 年度處於虧損；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故純益率及每股稅後盈餘皆由負轉正；110 年第一季純益率及每股稅後盈餘增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子

公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司純益率及每股稅後盈餘，108 年度華邦電之純益率及每股稅後盈餘亦較 107 年度下滑，惟該公司及其子公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司及其子公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司及其子公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；107 年度、109 年度及 110 年第一季之純益率及每股稅後盈餘介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司及其子公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

5.現金流量

(1)現金流量比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之現金流量比率分別為 68.88%、13.02%、54.64%及 13.18%，108 年度現金流量比率較 107 年度下降，主係該公司及其子公司 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願致營業收入減少，使 108 年營業活動淨現金流入減少所致；109 年度現金流量比率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營業活動淨現金流量增加所致；110 年第一季現金流量比率下降，營業收入相較去年同期增加 23.58%，使應收帳款總額較 109 年底增加 17.85%，使營業活動之淨現金流入略為下降，且 109 年營運狀況良好，該公司及其子公司將發放現金股利使流動負債略為增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司現金流量比率，108 年度低於採樣公司及同業平均，主係因該公司及其子公司 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，營業收入減少使得營業活動淨現金流入減少所致；107 年度、109 年度及 110 年第一季之現金流量比率介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司及其子公司之營運能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

(2)現金流量允當比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之現金流量允當比率分別為 84.14%、54.31%、75.83%及 78.71%，108 年度現金流量允當比率較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致營業收入減少，使 108 年營業活動淨現金流入減少所致；109 年現金流量允當比率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，營業活動淨現金流量增加所致；110 年第一季現金流量允當比率上升，主係因 110 年第一季半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、

平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司及其子公司營收成長、營業活動淨現金流量增加且尚未發放現金股利所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司之現金流量允當比率，107 年度高於採樣公司及同業平均，108 年度低於採樣公司及同業平均，主係因該公司及其子公司 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司及其子公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，使營運產生虧損所致，109 年度及 110 年第一季介於採樣公司及同業平均，整體而言，該公司及其子公司現金流量允當比率逐步健全，經評估應無重大異常情事。

(3)現金再投資比率

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季之現金再投資比率分別為 3.49%、0.73%、3.27%及 0.84%，108 年度現金再投資比率較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致營業收入減少，使 108 年營業活動淨現金流入減少所致；109 年度現金再投資比率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，營業活動淨現金流量增加所致；110 年第一季現金再投資比率下降，主係因營收成長，使應收帳款餘額隨之增加，且該公司及其子公司為營運需求，向銀行增加借款，致營運資金增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司及其子公司之現金再投資比率，107 年度介於採樣公司及同業平均，108 年度低於採樣公司及同業平均，主係因該公司及其子公司 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司及其子公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，使營運產生虧損所致，109 年度及 110 年第一季低於採樣公司及同業平均，然隨 109 年度營運由虧轉盈現金再投資比率逐漸上升，且與華邦電相當，整體而言，該公司及其子公司現金再投資比率逐步健全，經評估應無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及最近期現金流量之各項指標尚屬允當，與同業相較尚無重大異常情事。

(四)科技事業或文化創意事業申請股票上市者，應另列明其最近一個會計年度及最近期財務報告歸屬於母公司業主之權益，暨評估其申請上市年度及未來一年度歸屬於母公司業主之權益低於股本加計資本公積—發行溢價之合計數三分之二之可能性

單位：新臺幣仟元

項目	109 年 12 月 31 日	110 年 3 月 31 日
實收資本額	31,051,965	31,051,962
實收資本額之三分之二	20,701,310	20,701,308

歸屬於母公司業主之權益	33,217,689	33,958,594
歸屬於母公司業主之權益是否 達實收資本額之三分之二以上	是	是

資料來源：該公司經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司 109 年 12 月 31 日及 110 年 3 月 31 日合併財務報告歸屬於母公司業主之權益分別達實收資本額之 106.97%及 109.36%，均遠高於實收資本額之三分之二。此外該公司逐年獲利，營運績效隨著市場需求而增加，未來獲利成長應屬可期，故該公司申請上市年度及未來一年度歸屬於母公司業主之權益應可繼續達到實收資本額之三分之二以上。

二、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之最近期及最近三個會計年度背書保證、重大承諾及資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估其對發行公司財務狀況之影響

(一)背書保證

該公司已訂定「背書保證作業程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為辦理背書保證作業之依據。經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及背書保證備查簿等，該公司及其子公司最近三年度及最近期並無對他人背書保證之情事。

(二)重大承諾事項

經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及董事會議事錄等，該公司及其子公司之重大承諾事項及或有事項說明如下：

1.該公司分別於 92 年 8 月、94 年 3 月、97 年 6 月、99 年 3 月、10 月、100 年 7 月及 102 年 7 月與 Micron Memory Japan,Inc.(原 Elpida Memory Inc.)簽屬若干動態隨機存取記憶體技術移轉與授權合約，該公司承諾自技術移轉完成後 5 年內支付一定金額之技術授權費及依約定產品之售價給付一定比例之權利金。惟雙方另於 100 年 5 月及 102 年 7 月簽屬合作協議，修訂權利金支付比例。

2.該公司分別於 92 年 8 月及 94 年 3 月與 Hitachi 簽屬若干動態隨機存取記憶體技術之專利授權合約，該公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

3.該公司於 92 年 8 月與 Nec(Renesas)等簽屬若干動態隨機存取記憶體之專利技術授權合約，該公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

4.該公司於 108 年 7 月與愛爾蘭遠東金士頓公司簽訂代工合約至 110 年 10 月 31 日止，該公司承諾以約定價格為其製造記憶體產品。

5.該公司與環球晶簽訂長期矽原料進貨合約，以確保矽原料穩定供貨，其中約定該公

司須購買之相關最低數量及價格。

6.該公司與客戶 Mitsubishi Electric Corporation 簽訂晶圓製造合約，其中針對晶圓製造的部分機器設備，係由 Mitsubishi Electric Corporation 提供，該公司及其子公司需負保管及使用之責。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及最近期之重大承諾事項皆為正常營業之所需，故對該公司及其子公司財務狀況尚無重大不利影響。

(三)資金貸與他人

該公司已訂定「資金貸與他人作業程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為辦理資金貸與作業之依據。經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及資金貸與他人備查簿等，該公司及其子公司最近三年度及最近期未有資金貸與他人之情形。

(四)衍生性商品交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，業經董事會及股東會決議通過，另該公司之子公司亦已訂定相關作業程序作為其衍生性商品交易之依據。經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會與股東會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及衍生性金融商品備查簿等，該公司及其子公司最近三年度及最近期期末未到期之衍生性商品合約彙整如下：

單位：仟元

年度	交易類型	買入幣別及金額/賣出幣別及金額	交割日
107	賣出遠期外匯	NTD1,568,650/USD51,000	108.01.03~108.02.12
	賣出遠期外匯	JPY1,300,000/USD11,697	108.01.08~108.02.14
108	賣出遠期外匯	NTD152,300/ USD5,000	109.01.03
	賣出遠期外匯	JPY1,500,000/USD13,736	109.01.06~109.01.30
109	賣出遠期外匯	JPY2,350,000/USD22,553	110.01.07~110.02.08
110Q1	賣出遠期外匯	NTD222,320/USD8,000	110.04.01
	賣出遠期外匯	JPY1,300,000/USD11,895	110.04.01~110.04.22

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司最近三年度及最近期衍生性商品主要係遠期外匯，其目的為規避該公司及其子公司外幣資產及負債因匯率波動產生之風險，相關交易業已依「取得或處分資產處理程序」執行，應無重大異常之情事。

(五)重大資產交易

該公司及其子公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，業經董事會及股東會同意通過，另該公司之子公司亦已訂定相關作業程序作為其重大資產交易之依據。經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期公告明細、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、相關帳冊及董事會議事錄等資料，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季重大資產交易情形列示如下：

單位：新臺幣仟元

標的物名稱	取得日期				取得總價款	實際付款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者，其原取得資料				取得目的	價格決定之參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會決議日					日期	對象	與公司之關係	價格		
工程設施	107/5/30	-	107/05/31	-	620,000	依雙方約定	洋基工程股份有限公司	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	107/9/25	-	107/10/01	-	682,676	依雙方約定	Applied Materials South East Asia Pte, Ltd	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/5/02	-	108/05/03	-	2,580,369	依雙方約定	香港商艾司摩爾貿易有限公司台灣分公司	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：董事長
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/05/08	-	108/05/09	-	1,031,927	依雙方約定	TOKYO ELECTR ON LIMITED	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/05/08	-	108/05/09	-	1,425,668	依雙方約定	Applied Materials South East Asia Pte, Ltd	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/6/28	-	108/06/28	108/6/28	USD100,589	依合約議定，分期支付	Mitsubishi Electric Corporation	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：依雙方約定 (2)價格決定之參考依據：依雙方約定。 (3)決策單位：董事會

標的物名稱	取得日期				取得總價款	實際付款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者，其原取得資料				取得目的	價格決定之參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會決議日					日期	對象	與公司之關係	價格		
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/10/21	-	108/10/22	-	1,263,951	依雙方約定	Integrated Silicon Solution, Inc.	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：依雙方約定 (2)價格決定之參考依據：依雙方約定。 (3)決策單位：總經理
收購母公司全部或主要部分之相關營業(含資產、負債及營業)	107/9/4	108/5/1	107/9/4	107/9/4	22,608,182	以每股發行價格新臺幣 10 元計算，該公司計發行新股 2,260,818,220 股	力晶科技股份有限公司	母公司	84.08.12~108.04.30	ASML Hong Kong Ltd. c/o ASML Netherlan ds B.V.、TOKYO ELECTR ON LIMITED、APPLIED MATERIALS Asia-Pacif ic, Ltd 及 其他…等	-	22,608,182	註 1	(1)交易之決定方式：董事會決議通過 (2)價格決定之參考依據：財團法人中華民國會計研究發展基金會(105)基秘字第 321 號「共同控制下子公司合併另一 100%持有之子公司之財務報表表達疑義」，共同控制下之合併個體性質為組織重組；故應按收購讓與基準日之原資產帳面價值 (3)決策單位：董事會 (4)取得外部專家意見:勤業眾信資產負債查核結果函、聯緯事務所合理意見書
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/3/9	-	109/3/9	109/3/9	1,000,000	依雙方約定	智豐料技股份有限公司	實質關係人	103.10～107.07	HIKE、東典、英福康、LAMRI、久福、恆鑫、EBARA、Edwards、Canon、AMAT、漢氏、崇越、PSK、NISSIN-ION 及其他等	-	1,481,246	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：雙方議定 (2)價格決定之參考依據：雙方議定。 (3)決策單位：董事會 (4)取得外部專家意見：展茂資產管理顧問股份有限公司及詠宸資產評價有限公司 (5)配合生產製程計劃及資金規劃，故向智豐買回 consign 設備一批，供晶圓產品生產製造使用
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/10/30	-	109/10/30	109/10/30	1,620,000	依雙方約定	聯發科技股份有限公司	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：雙方約定 (2)價格決定之參考依據：雙方約定。 (3)決策單位 ：董事會決議
興建廠房用之鋼構材料	109/12/18	-	109/12/19	-	1,820,000	依雙方約定	東鋼鋼結構股份有限公司	無	-	-	-	-	供建置廠房使用	(1)交易之決定方式：比價及議價

標的物名稱	取得日期				取得總價款	實際付款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者，其原取得資料				取得目的	價格決定之參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會決議日					日期	對象	與公司之關係	價格		
														(2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：董事長
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/3/12~109/12/24	-	109/12/25	-	1,120,610	依雙方約定	Applied Materials South East Asia Pte.Ltd.	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/3/26~110/2/8	-	110/2/8	-	1,014,544	依雙方約定	TOKYO ELECTRON LIMITED	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：組織重組發行新股收購母公司力晶科技股份有限公司全部或主要部分之相關營業(含資產、負債及營業) (依企業併購法第 28 條)；故應按收購讓與基準日之原資產帳面價值入帳。

該公司及其子公司考量滿足公司營運規劃所需，陸續購買半導體產品生產製造設施、機器設備及興建廠房用之鋼構材料等，上述重大資產交易案為金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之二十以上，交易過程均係依「取得或處分資產處理程序」規定辦理，交易係由多筆採購彙總，已依內部決策過程經核決層級核決通過，或已按照「取得或處分資產處理程序」提報董事會通過，其交易目的與決策過程尚無重大異常之情事，對該公司及其子公司之財務狀況尚不致產生重大不利之影響。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及最近期並無背書保證、資金貸與他人之情事，而衍生性商品、重大承諾及重大資產交易之情形，皆為正常營運發展所需，尚無重大異常情事，故對該公司及其子公司財務狀況尚無重大影響。

三、列明申請年度截至最近期止擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，包含邏輯產品及記憶體產品兩種領域，為臺灣少數同時可以製造記憶體及邏輯產品之晶圓製造公司。根據 WSTS(全球半導體貿易統計協會)統計 109 年全球半導體，市場產值達 4,330 億美元，較 108 年的 4,123 億美元增長 5.1%，較先前受新型冠狀病毒(COVID-19)影響下修至 3.3%的成長預期為優。WSTS 預計 110 年全球半導體市場增長將加速，110 年全球半導體產值可望年增約 8.4%，主要成長動能來自於 Sensor、Logic 及 Memory 等相關產品；研調機構顧能 Gartner 也預期 110 年半導體市場將成長 11.6%以上水準。由於 5G、AI、IOT、電動車等各項應用大爆發，晶片的需求大於供給，促使晶圓代工需求大爆發，整體產業狀態明顯供不應求。

為因應前述產業發展，該公司及其子公司的資本支出計畫主要包括兩個議題：一是產能去瓶頸化：既有廠房的改善專案、產能擴充與配置；另一則為擴建新廠—銅鑼廠。分述如下:

(一)產能去瓶頸化專案

1.計畫內容

因應市場需求增加，協助既有 8A、8B、P1/2 及 P3 廠產能去瓶頸，為因應未來營運發展規畫，擬購置機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施以擴充產能、提升生產製程及增進研發能力。去瓶頸化專案計畫項目及相關內容如下:

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預訂完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度					
			110 年度		111 年度			
			第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施	111 年第四季	12,000,984	3,460,634	620,685	3,334,029	418,339	2,410,868	1,756,429

資料來源：該公司及其子公司提供

2.資金來源

(1)現金增資發行普通股 300,000 仟股，每股面額新臺幣 10 元，每股溢價發行價格為新臺幣 40 元，募集總金額為新臺幣 12,000,000 仟元。

(2)自有資金：984 仟元。

3.工作進度

由於生產機台的部分要依照客戶需求進行採購，目前仍在進行中。

4.預計效益

該公司及其子公司為因應未來營運發展規畫，擬購置機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施以擴充產能、提升生產製程及增進研發能力，該次現金增資發行新股募集資金為新臺幣 12,000,000 仟元，將全數用於支應上述所需，其餘新臺幣

984 仟元係由自有資金支付，預估 110 年下半年至 115 年度共可增加營業收入新臺幣 34,062,688 仟元及增加營業利益新臺幣 8,828,892 仟元，預計自 110 年第三季起算，並以現金基礎推算其資金回收年限約為 5.4 年。

(1)本次購置機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施預產生之效益

單位：新臺幣仟元；仟片

年度	主要產品	生產量增加	銷售量增加	銷售額增加	營業毛利增加	營業淨利增加
110 年	晶圓代工	45	45	1,311,317	444,793	339,887
111 年	晶圓代工	196	196	5,571,075	1,889,683	1,443,997
112 年	晶圓代工	245	245	6,795,074	2,304,858	1,761,252
113 年	晶圓代工	245	245	6,795,074	2,304,858	1,761,252
114 年	晶圓代工	245	245	6,795,074	2,304,858	1,761,252
115 年	晶圓代工	245	245	6,795,074	2,304,858	1,761,252
合計				34,062,688	11,553,908	8,828,892

資料來源：該公司及其子公司提供
註：銷售量係以 12 吋晶圓約當片數計算

(2)預計資金回收年限

單位：新臺幣仟元

年度	營業淨利(A)	折舊費用(B)	現金流入(A+B)	累積現金流入
110 年	339,887	85,466	425,353	425,353
111 年	1,443,997	519,223	1,963,220	2,388,573
112 年	1,761,252	765,314	2,526,566	4,915,139
113 年	1,761,252	765,314	2,526,566	7,441,705
114 年	1,761,252	765,314	2,526,566	9,968,271
115 年	1,761,252	765,314	2,526,566	12,494,837

資料來源：該公司及其子公司提供
註：機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施等之折舊攤提年限為 12~26 年不等，依本次擬購置之全數設備投產後計算，每年應攤提之折舊費用約為新臺幣 765,314 仟元。

5.可行性評估

(1)資金募集計畫之可行性

本次計畫辦理現金增資發行普通股 300,000 仟股，已於 110/3/19 取得金管會證期局金管證發字第 1100335468 號函核准 110/6/11 收足股款，故本次現金增資計畫應屬可行。

(2)資金運用計畫之可行性

本次辦理現金增資所募集之資金為新臺幣 12,000,000 仟元，將全數用於購置機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施。受惠於到新冠肺炎疫情影響宅經濟發燒及 5G 相關設備滲透率之提升，致對電源應用之相關需求數量成長，為因應客戶需求，本次購入之機器設備將配合現有廠房空間購置安裝，所購置之機器設備用以擴增產能、提升生產製程能力及增進研發能力，機器設備包括晶圓清洗機、晶圓背面蝕刻機、金屬層濺鍍機及深紫外光掃描機/曝光機等，依該公司之

資本規畫進度分別下單採購、安裝及啟用生產。由於本次採購之機器設備與現有生產晶圓代工之設備相同，且本次採購機器設備之計畫進度係據過往經驗及各相關專業人士進行規畫，主要機器設備採購係依循過去裝設經驗進行規劃，故購置機器設備計畫進度應屬可行。

本次擬購置之機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施及其金額明細如下表：

單位：新臺幣仟元

機器設備名稱	金額
晶圓清洗機	2,310,406
晶圓背面蝕刻機	1,576,035
金屬層濺鍍機	1,337,108
深紫外光掃描機/曝光機	898,223
缺陷檢測機	839,760
化學氣相沈積	677,344
化學機械研磨	558,720
快速升降溫機台	530,208
晶片鍵合機	484,352
汽相沉積垂直爐管	390,464
自動化設備	300,597
電子束圖案檢測顯微鏡	267,960
明場顯微鏡	222,985
光罩儲存機	204,502
曝光後圖案重合檢查機	203,584
鎳矽動態表面快速退火裝置	197,582
掃瞄式電子顯微鏡	147,398
濕蝕刻機台	131,564
尾氣處理設備	106,985
曝光後圖案重合量測機	76,500
晶圓測試機	76,238
金屬前去光阻機	75,335
離子植入機	70,365
雙迴路供電系統	60,380
膜厚量測機台	59,235
先進製程液體供應系統	50,000
廠務工程	34,440
晶片鍵合檢測機	32,296
改機配件	28,003
晶圓針測機/測試機	27,415
裝機工程及防震台	20,000
高溫晶片烤箱	5,000
總計	12,000,984

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司本次擬購買機器設備之產製流程與現有晶圓之生產線大致相同，操作方式應不至有太大差異，且經營管理幹部之生產經驗豐富，在原有工作人員之經驗與技術皆成熟情況下，對新機器設備之操控及順利運轉，生產應

無疑慮，且該公司位於新竹科學園區人力資源豐沛，故本次計畫購買機器設備生產之技術來源及人力取得應屬可行。

(二)銅鑼廠(簡稱 P5 廠)

1.計畫內容

由於晶圓廠建廠計畫是需要長時間擘劃的，107 年便開始規劃，於 109 年 8 月正式啟動，全案規劃於 10 年內分階段投資，將視市場需求及公司財務能力逐年擴充產能，預估總投資金額達新臺幣 2,780 億元，將於竹科銅鑼園區，興建兩座晶圓廠，共計 53,000 平方公尺的無塵室面積，10 萬片/月的產能規劃，屆時完工後將可為竹苗地區帶來 3,000 個優質工作機會。

P5 廠目前已開始廠房興建工程之籌劃與初期工程，第一階段工程將打造月產能 3 萬片之無塵室，預計將於 111 年下半年完工，共計需投入新臺幣 272 億元，未來將視市場需求及該公司規劃逐步擴建。

2.資金來源

P5 廠第一期至 111 年底資金需求預計為新臺幣 272 億元，109 年 8 月 P5 計畫正式啟動，110 年 3 月正式動土，截至 110 年 6 月底止已投入 2 億元，該公司及其子公司預計 110 下半年、111 年至 113 年將分別再投入 47 億元、170 億元、30 億及 23 億元；未來辦理股票初次上市之現金增資所取得之資金將會依照資金運用進度，優先用於建物/廠務與自動化等資本支出，尚有不足者，則以自有資金或銀行融資支應。

3.工作進度

P5 廠區，計畫興建總建築面積為 46,399 平方公尺，預計興建一棟晶圓製造廠房、一棟行政大樓及一棟廠務、水電、氣化空調的中央供應站；目前整個建廠案已經在今年 3 月動土，預計明年下半年無塵室完工後便可陸續展開小規模試產。

4.預計效益

由於晶圓代工製造會隨著 IC 設計客戶投產的產品差異很大，所需投入之機台設備亦會有所不同，目前雖有多方 IC 設計客戶與該公司及其子公司洽談中，惟該新廠之最適產品組合仍在調配中，故目前尚無法明確評估廠房營運後對公司帶來的效益，不過籌設新廠除了可以提供一個足供未來 20-30 年穩定發展的生產基地外，較之於承租舊有廠房，可以節省下數億元的改建費用，另外每年也可省下數仟萬元的租金支出。

5.可行性評估

(1)預計效益之可行性

依照該公司及其子公司承租 8AD 廠及購買 8B 廠改建經驗，由於舊有建築物並非專門供晶圓廠使用，機台擺設位置、各工作站動線安排、樓地板荷重程度、

倉儲與出貨動線等皆須要經過規劃與修改，依照建築物屬性不同，投入改建的資金也會有所不同。如果自行興建應可達到最佳的空間規劃與節省改建支出。

經查詢工業用地供給資訊平台，新竹苗栗地區大面積廠房租金行情。以本次興建的面積，每年約可節省新臺幣 8,400 萬元。

(2)資金來源之可行性

依照該公司及其子公司的 Open Foundry 策略，去年已有聯發科宣布在 16.2 億元額度內買設備出租給力積電，更早也有金士頓也採用類似概念與力積電合作。為因應熱絡的晶圓代工產能需求，現在越來越多 IC 設計客戶已經能夠接受為搶產能，預先提供資金予晶圓廠興建製程產線。機器設備尚待與客戶作整體規劃才能確定資本支出。另以新建廠房及自動化工程資金需求為新臺幣 272 億元，預計申請上市時辦理現金增資發行新股 200,000,000 股，將於年底前資金到位用於支應該工程，若有不足，該公司及其子公司截至 110 年 6 月底現金為新臺幣 228 億元，且銀行融資額度尚未動用者尚有新臺幣 125 億元，另從該公司及其子公司最近年度及最近期分別產生 9,638,179 仟元及 2,353,293 仟元的營運活動淨現金流入，可產出穩定的現金流。綜上所述，本次擴廠計劃資金來源應具有可行性。

(3)土地使用權取得及興建之可行性

該公司及其子公司已與科技部新竹科學園區管理局簽訂土地租賃契約，取得確切期間之土地使用權，於 110 年 3 月動土，經評估該公司及其子公司對於擴廠計畫之土地使用權取得及廠房建造均屬可行。

(4)機器設備購置及安裝之可行性

由於該公司及其子公司已有多座晶圓廠，且因應不同客戶需求，每年度也有既定的設備採購支出，故機器設備購入應無障礙。且各項機器設備使用及安裝技術已累積相當經驗，故其產線建置測試及投入量產應無困難，綜上所述，該公司及其子公司在廠房之機器設備購置及安裝尚屬可行。

(5)財務可行性

上述擴廠計畫除了已投入之土地使用成本、廠房建設款及機器設備款外，尚有部分資金須持續投入，其付款主要依照未來廠房興建開工時點、廠房建造進度及機器設備安裝驗收進度付款。該公司及其子公司截至 110 年 6 月底現金為新臺幣 228 億元，且該公司及其子公司後續仍有增資計畫、銀行借款，也可要求客戶預先購買產線設備，也能產生穩定現金流，故該公司及其子公司應足以支應相關建廠之款項。

綜上所述，該公司及其子公司上述之擴廠計畫之資金來源、工作進度及預計效益經評估尚屬合理可行。

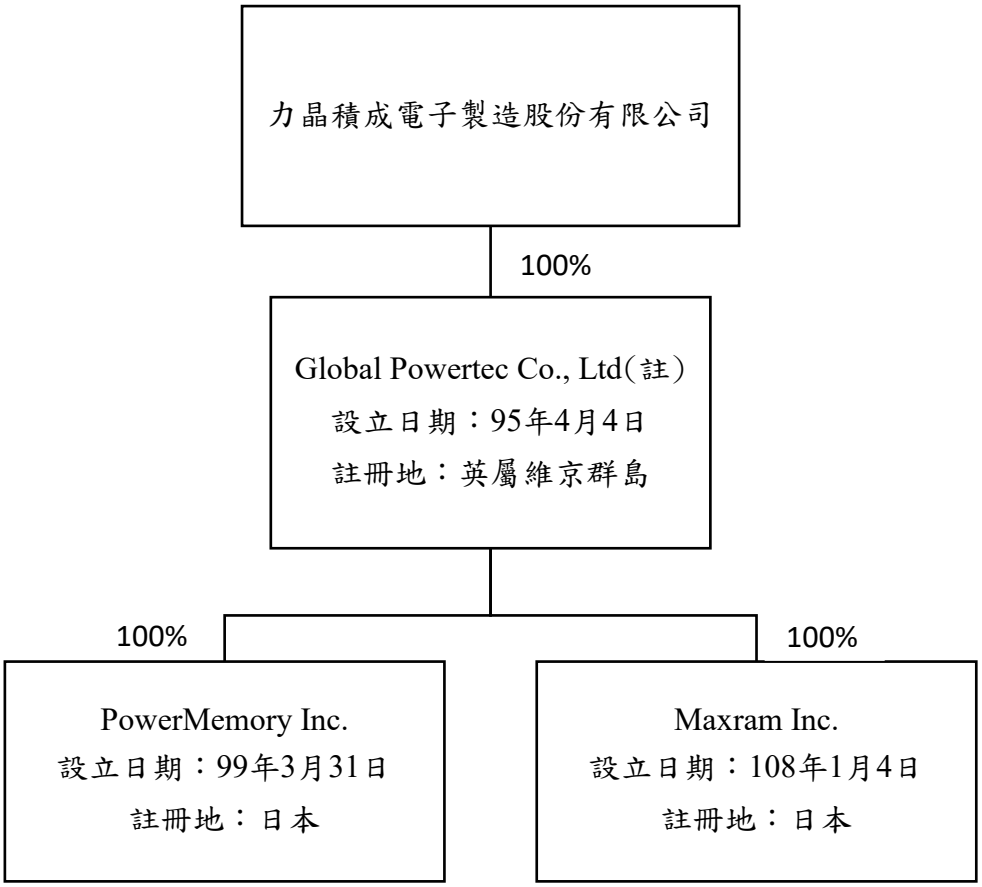
四、發行公司及其各子公司(包括母子公司間交易事項)之轉投資事業

(一)列明申請年度截至最近期財務報告止概況並評估重要轉投資事業(持股比例達百分之二十以上或帳面金額或原始投資金額達新臺幣五仟萬元以上)最近期及最近一個會計年度之營運及獲利情形、最近期及最近三個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形(海外轉投資事業一併列明獲利匯回金額)，若有利用發行公司資源及技術之情形，其給付對價或技術報酬金之合理性，若截至最近一期，轉投資事業發生營運或財務週轉困難情事，並應評估對發行公司之影響

1.轉投資事業概況

(1)重要轉投資事業圖

資料日期：110.03.31



資料來源：該公司及其子公司提供

註：該公司 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業，並由該公司發行新股予力晶公司作為收購之對價；及由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.讓與該公司。

(2)轉投資事業一覽表

直接轉投資事業

單位：原幣；新臺幣仟元；股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	投資年度	投資目的	評價方法	原始投資狀況			110年03月31日				
						金額	股數	持股比例	帳面金額	股數	持股比例	每股面額(元)	股權淨值
Global Powertec Co., Ltd	從事各式投資業務	英屬維京群島	註1	投資控股	權益法	1	1	100%	(70,780)	1	100%	USD10	(70,780)

資料來源：110 年第一季經會計師核閱之合併財務報告

註 1：該公司 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業，並由該公司發行新股予力晶公司作為收購之對價；及由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.讓與該公司。

間接轉投資事業

單位：新臺幣仟元；股

轉投資事業	主要營業項目	設立地區	投資年度	投資目的	評價方法	原始投資狀況			110年03月31日				
						金額	股數	持股比例(%)	帳面金額	股數	持股比例(%)	每股面額(元)	股權淨值
PowerMemory Inc.	從事半導體及電子產品開發、製造、銷售及輸出入	日本	註1	Flash製程相關設計及研發	權益法	703,165	500,000	100%	14,111	500,000	100%	JPY100	14,111
Maxram Inc.	從事半導體及電子產品開發、製造、銷售及輸出入	日本	註2	DRAM製程相關設計及研發	權益法	22,415	799,900	100%	12,122	799,900	100%	JPY100	12,122

資料來源：110 年第一季經會計師核閱之合併財務報告

註 1：該公司 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購母公司力晶公司全部或主要部分之相關營業，並由該公司發行新股予力晶公司作為收購之對價；及由力晶公司將持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.讓與該公司。

註 2：Global Powertec Co., Ltd.於 108 年 3 月 22 日取得 Maxram Inc. 100%之股權。

2.重要轉投資事業投資過程

該公司截至評估報告出具日止，直接或間接持股比率達 20%以上或帳面金額或原始投資金額達新臺幣五仟萬元以上之轉投資事業共計有 3 家，其中該公司直接持股之轉投資公司包括 Global Powertec Co., Ltd；間接持股之轉投資公司係 PowerMemory Inc.及 Maxram Inc.。茲將該公司轉投資事業之投資目的、決策過程、股權取得情形及合理性說明如下：

(1)Global Powertec Co., Ltd

該公司於 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組而收購力晶科全部或主要部分之相關營業、資產及負債，其中包含力晶科直接及間接持股 100%之 Global Powertec Co., Ltd.(以下簡稱 Global Powertec)、PowerMemory Inc.與 Maxram Inc.，並由該公司發行新股予力晶科作為收購之對價。該項投資案係經 107 年 9 月 4 日董事會決議通過收購力晶科全部或主要部分之營業或財產，並與力晶科簽訂營業與資產收購合約，約定收購與讓與基準日為 108 年 5 月 1 日。取得該等轉投資事業帳列為採用權益法之投資，於讓與基準日帳列金額為貸餘 41,961 仟元，該公司業已委請勤業眾信聯合會計師事務所鍾鳴遠會計師出具讓與資產及負債項目查核結果，並請聯緯聯合會計師事務所呂仁琦會計師出具價格合理性意見書。該公司於 108 年 5 月 7 日董事會討論該營業讓與結果。經評估其決策過程、投資目的與取得價格尚屬合理。

(2)PowerMemory Inc.

該公司經營業讓與取得 Global Powertec 之轉投資公司 PowerMemory Inc.，主係從事 Flash 製程相關設計及研發，截至 110 年 3 月 31 日止，持股比例為 100%。經評估其決策過程與投資目的尚屬合理。

(3)Maxram Inc.

該公司經營業讓與取得 Global Powertec 之轉投資公司 Maxram Inc.，主係從事 DRAM 製程相關設計及研發半導體及電子產品開發、製造、銷售及輸出入。受讓 Maxram Inc.後，該公司於 108 年由 Global Powertec 對其進行增資 8,510 仟元。截至 110 年 3 月 31 日止，該公司對 Maxram Inc.持股比例為 100%，經檢視其決策過程與投資目的尚屬合理。

3.重要轉投資事業股權變動情形

單位：股；仟元

轉投資公司	原始投資				股權變動					截至 110 年 3 月 31 日累積投資金額		
	年度	股數	金額	持股比例	年度	變動原因	增(減)股數	增(減)金額	持股比例	股數	金額	持股比例
Global Powertec	108	1	1	100%	108	-	-	-	-	1	1	100%
					109	-	-	-	-			
					110Q1	-	-	-	-			
PowerMemory	108	500,000	703,165	100%	108	-	-	-	-	500,000	703,165	100%
					109	-	-	-	-			
					110Q1	-	-	-	-			
Maxram	108	10,000	278	100%	108	增資	490,000	13,627	100%	799,900	22,415	100%
					108	增資(註 1)	299,900	8,510	100%			
					109	-	-	-	-			
					110Q1	-	-	-	-			

註 1：係於力積電受讓後對 Maxram 進行之增資，於 108 年 12 月 5 日股本登記完成。

該公司之轉投資事業主係考量集團未來整體發展，截至 110 年 3 月 31 日止，該公司直接或間接投資之轉投資事業持股比例皆為 100%，經評估該公司轉投資事業之股權變動情形，尚無重大異常之情事。

4.發行公司及其各子公司對轉投資事業之管理政策

該公司對於轉投資事業之管理政策係依據內部控制制度或相關作業程序辦理，除訂有「子公司監理作業辦法」外，並訂有「關係人交易管理辦法」，做為各公司財務、業務往來之依循規範。另子公司亦訂定有內部控制制度，以確保公司之健全經營。該公司定期取得各子公司之營運及財務資料，除可持續瞭解各子公司之財務或業務狀況外，亦可確實有效的控管其經營績效，茲就該公司對轉投資事業之監理作業說明如下：

(1)經營管理之監理

各轉投資公司之董事及監察人人數係依當地法令規定設立，由該公司董事長指派適任人員擔任轉投資公司之董事及監察人，並取得適當席次。各轉投資公司之經理人由各轉投資公司董事會依法聘任。各轉投資公司之經營階層除能充分發揮自主決策能力外，並隨時與該公司保持良好溝通與密切合作之關係。

(2)財務業務之監理

依據子公司監理作業辦法規定，各轉投資公司在財務管理上應配合該公司之財務政策，以獨立自主之方式執行各項財務管理，並需符合當地之會計與稅務規定。該公司每月定時檢視各轉投資公司之各項財務管理報表，掌握各轉投資事業之經營成果及財務狀況，藉以評估各轉投資事業之經營績效。

(3)對子公司稽核之監理

該公司稽核單位係將各轉投資公司納入內部稽核範圍，並定期或不定期安排稽核專案對子公司進行稽核；稽核報告之發現及建議於呈核後，應通知各受查之各轉投資公司改善，並定期作成追蹤報告，以確定其已及時採取適當之改善措施。

5.重要轉投資事業最近期及最近一個會計年度營運及獲利情形

單位：仟元

轉投資事業	109 年度		110 年第一季	
	營業收入	稅後(損)益	營業收入	稅後(損)益
Global Powertec Co., Ltd	0	(20,719)	0	8,837
PowerMemory Inc.	87,325	(1,802)	27,762	6,463
Maxram Inc.	76,890	2,127	30,324	5,207

資料來源：該公司及其子公司提供

(1)Global Powertec Co., Ltd

Global Powertec Co., Ltd 係該公司持有 100%之子公司，主係從事各式投資業務，109 年度帳列虧損與 110 年度第一季帳列利益，除了認列轉投資之損益外，主要是利息支出及兌換損失，並無重大異常之情事。

(2)PowerMemory Inc.

PowerMemory Inc.係該公司持有 100%之子公司，主係從事半導體及電子產品開發、製造、銷售及輸出入，109 年度與 110 年度第一季主要收入來源為開發收入，並無重大異常之情事。

(3)Maxram Inc.

Maxram Inc.係該公司持有 100%之子公司，主係從事半導體及電子產品開發、製造、銷售及輸出入，109 年度與 110 年度第一季主要收入來源為開發收入，並無重大異常之情事。

6.最近期及最近三個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、股利分配情形(海外轉投資事業一併列明獲利匯回金額)

單位：仟元

轉投資事業	投資損益				股利分配情形				獲利匯回金額			
	107年	108年	109年	110年第一季	107年	108年	109 年	110年第一季	107年	108 年	109 年	110 年第一季
Global Powertec Co., Ltd	-	(15,184)	(20,719)	8,837	-	-	-	-	-	-	-	-
PowerMemory Inc.	-	1,387	(1,802)	6,463	-	-	-	-	-	-	-	-
Maxram Inc.	-	(16,716)	2,127	5,207	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：該公司及其子公司提供

最近三年度及申請年度截至最近期止，該公司認列投資金額係依據各子公司之持股比例認列，此外，因各轉投資事業尚無獲利或獲利不大，故未有股利分配及獲利匯回之情事。

7.重要轉投資事業給付發行公司技術報酬金情形

截至評估報告出具日止，該公司之轉投資事業並無支付該公司技術報酬金之情事。

8.截至最近一期，若轉投資事業發生營運或財務週轉困難情事，應評估對發行公司之影響

截至評估報告出具日止，該公司轉投資事業並無發生營運或財務週轉困難之情事。

(二)已赴或擬赴大陸地區從事投資者，應敘明其投資情況與最近期及最近三個會計年度認列採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額、獲利匯回金額，並評估其對發行人財務狀況之影響

截至評估報告出具日止，該公司並無已赴或擬赴大陸地區從事投資之情事，故不適用本項評估。

(三)申請年度截至最近期財務報告止尚未完成之投資案，其預估總投資金額占最近一個會計年度實收資本額百分之二十以上，或逾新臺幣五億元者，應就下列事項詳加評估說明；無面額或每股面額非屬新臺幣十元之發行人，前開有關實收資本額百分之二十之計算應以歸屬於母公司業主之權益百分之十替代之

截至評估報告出具日止，該公司及其子公司並無尚未完成之投資案，故不適用本項評估。

五、承銷商依臺灣證券交易所股份有限公司「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條規定實地輔導發行公司之重要子公司者，應列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見

該公司及其子公司最近年度及申請年度最近期轉投資事業中未有符合「證券承銷商辦理股票初次申請上市案之評估查核程序」第六條及「會計師查核簽證財務報表規則」第二條之一第二項規定之重要子公司，故不適用本項評估。

六、評估發行公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至之員工認股權憑證採內含價值法，於發行公司股票上市後對財務報表可能之影響

該公司及其子公司截至評估報告出具日止已發行未屆期之員工認股權憑證彙總如下表：

員工認股權憑證種類	董事會通過日期及數量	各階段董事會通過日期及數量	發行日	流通在外單位數	每股認購價格	評價方式
第一次員工認股權憑證	108/12/24 董事會通過發行總數 150,000,000 單位(1 股/單位)。	109/1/20 董事會通過第一階段發行 138,440,000 單位	109.01.21	138,440,000 股	新臺幣 10 元	公平市場價值
		109/11/13 董事會通過第二階段發行 11,560,000 單位	109.11.16	11,560,000 股	新臺幣 14.8 元	公平市場價值
第二次員工認股權憑證	109/10/30 董事會通過發行總數 300,000,000 單位(1 股/單位)。	109/11/13 董事會通過第一階段發行 268,969,000 單位	109.11.16	268,969,000 股	新臺幣 14.8 元	公平市場價值
		110/3/9 董事會通過第二階段發行 926,000 單位	110.03.09	926,000 股	新臺幣 63.6 元	公平市場價值

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司發行員工認股權憑證係為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。該公司及其子公司第一次員工認股權憑證於 108 年 12 月 24 日經董事會決議發行員工認股權憑證 150,000,000 單位，並於 109 年 1 月 6 日取得金管會申報生效之核准函；該公司及其子公司配合主管機關要求修正第一次員工認股權憑證發行及認股辦法後，於 109 年 11 月 13 日經董事會追認通過。

該公司及其子公司第二次員工認股權憑證於 109 年 10 月 30 日經董事會決議發行員工認股權憑證 300,000,000 單位，並於 109 年 11 月 10 日取得金管會申報生效之核准函；該公司及其子公司配合主管機關要求修正第二次員工認股權憑證發行及認股辦法後，於 109 年 11 月 13 日經董事會追認通過。

該公司及其子公司第一次與第二次員工認股權憑證，因發行未屆滿二年，故均尚未執行認股權。且該公司及其子公司發行之員工認股權係依照國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」之規定，採用 Black-Scholes 選擇權評價模式，估計給與日股份基礎給付之公平價值計算酬勞成本，非採用內含價值法衡量，故應不影響上市後財務報表之損益。

七、公營事業申請股票上市時，其檢送之財務報告有未經會計師簽證者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見。

該公司及其子公司非屬公營事業申請股票上市，故不適用本項評估。

八、金融事業申請股票上市，應列明其備抵提列情形，並評估其是否足額。

該公司及其子公司非屬金融事業申請股票上市，故不適用本項評估。

九、承銷商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響

該公司及其子公司非屬外國申請公司，故不適用本項評估。

伍、承銷商得視發行公司所營事業性質，委請在技術、業務、財務等各方面具備專業知識及豐富經驗之專家，就發行公司目前營運狀況及未來發展，進行比較分析，並本獨立公正立場出具審查意見，俾利評估

本證券承銷商並無委請專家出具審查意見書，故不適用。

陸、法令之遵循及對本國發行公司營運影響由承銷商洽律師對本國發行公司、現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人最近三年內就下列事項出具意見後，依據其意見承銷商評估對本國發行公司營運影響及因應之道，並說明影響此次承銷之因素：

本承銷商洽請翰辰法律事務所邱雅文律師，對該公司、其現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人最近三年內就下列事項出具法律意見書，並依據該法律意見書評估對該公司營運之影響暨其因應措施是否完整與妥適，彙總說明如下：

一、發行公司是否違反相關法令規章

(一)發行公司所屬行業之目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章。

該公司所營事業非屬特許行業，無需特別許可即得經營，其目的事業中央主管機關為經濟部，影響該行業之重要法律大致上可分為公司法、證券交易法、商業會計法、商業會計處理準則、勞動基準法、職業安全衛生管理法及其相關法規、廢棄物清理法、所得稅法、加值型及非加值型營業稅法、促進產業升級條例、公平交易法、著作權法、專利法及商標法等相關法令等，經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並核閱該公司與主管機關往來函文，該公司最近三年度及申請年度截至出具意見書日止，該公司並無違反該行業之目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章之情事。

(二)該公司依公開發行公司資訊公開相關法令應公開之資訊，評估是否依其法令辦理

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並查閱該公司與主管機關往來函文及取得相關聲明書，其中該公司係有於 109 年 12 月底發生二筆未即時進行發布重大訊息之情事，主係因此二筆為該公司取得核准公開發行公司後首次遇到應辦理公告之情事，該公司已完成作業之改善流程並向各單位加強宣導相關應注意事宜，截至目前為止，並無發生其他未依公開發行公司資訊公開相關法令規定辦理之情事。

(三)其他法令規章，例如公平交易法之實施

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並查閱該公司與主管機關往來函文及取得相關聲明書，截至評估報告出具日止，該公司最近三年度迄今未發現有違反其他法令規章之情事。

二、董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，查閱法源法律網之判決書資訊，並取得上述人員之聲明書、財團法人金融聯合徵信中心無退票記錄、第一類票據信用資料查覆單、無欠稅證明文件及投資人及期貨投資人保護中心函文等資料，截至評估報告出具日止，除該公司董事黃崇仁、邵章榮有下列情事外：

(一)董事長黃崇仁 108 年度綜合所得稅經國稅局核定有一筆利息收入，核定應補繳稅額新臺幣 36,099 元，係董事長黃崇仁於 104 年借款予他人，惟借款人至今並未償還本

金及利息故並無利息收入，董事長黃崇仁並已向國稅局申請更正。上述情事，目前尚於國稅局審理中，最終若認定須繳稅，僅需繳款並不會有違反稅捐稽徵法之情事。

(二)董事邵章榮 108 年度綜合所得稅經國稅局核定有一筆租賃收入，核定應補繳稅額新臺幣 32,499 元，邵章榮董事並無國稅局所核定之租稅收入並已向國稅局申請更正。上述情事，目前尚於國稅局審理中，最終若認定須繳稅，僅需繳款並不會有違反稅捐稽徵法之情事。

(三)董事長黃崇仁先生，於民國 94、95 年間擔任力晶半導體股份有限公司（力晶科技股份公司前名稱，下稱力晶公司）董事長時，因董事長職業關係獲悉力晶公司與旺宏電子股份有限公司(下稱旺宏公司)間「買賣晶圓三廠廠房」與「策略聯盟」之重大消息，卻於該消息於 95 年 1 月 18 日公開前即利用力晶集團證券帳戶購買旺宏公司股票，本案黃崇仁最終為無罪確定，故並無有期徒刑以上之罪。其遭投保中心請求侵權行為的損害賠償案，高等法院判決應支付賠償款新臺幣 463 仟元。

該公司現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員並無違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務行使之情事。

三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並查閱公司歷次股東會及董事會會議記錄、公司股東會年報、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，並詢問該公司管理階層及取得該公司出具之聲明書等，截至評估報告出具日止，尚無發現該公司有違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事。

四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，查閱該公司董事會議事錄、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，並取得該公司及其現任董事出具之聲明書，截至評估報告出具日止，除該公司董事力晶科技股份有限公司、黃崇仁有下列案件外，並無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：

(一)日本鎧俠股份有限公司(原名東芝記憶體股份有限公司，下稱鎧俠公司)於民國 103 年 5 月 30 日以力晶科技股份有限公司等公司(下稱力晶等公司)所製造、銷售之 NAND Flash Memory 產品(下稱系爭產品)侵害其二 NAND 快閃記憶體專利(下稱系爭專利)為由，向台灣智慧財產法院起訴請求力晶等公司及力晶公司負責人黃崇仁應連帶賠償新臺幣 2 億元、力晶等公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品及其他一切侵害系爭專利之產品、力晶等公司應回收並銷毀侵權產品。智慧財產一審法院於 106 年 7 月 5 日判決鎧俠公司部分勝訴(包含力晶公司及黃崇仁應連帶給付鎧俠公司 2 億元、力晶等公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口部分產品、力晶等公司應回收並銷毀侵權產品)，兩造不服提起上訴，智慧財產二審法院於 108 年 10 月 3 日以系爭專利有得撤銷事由為由判決鎧俠公司全部敗訴。鎧俠公司不服提起上訴，本案目前尚於最高法院審理中。力晶公司雖有上開訴訟，惟力晶公司業已委任律師處理本案，並已提列等額之負債準備，且本案為力晶公司本身之訴訟，與力積電公司無涉，故本案訴訟結果亦尚不致對力積電公司之財務、業務生重大影響。

(二)矽創電子股份有限公司(下稱矽創公司)於 107 年 2 月 14 日主張格科微電子(上海)有限公司(下稱格科微)與力晶科技股份有限公司(下稱力晶公司)共同侵害矽創公司之「節省電路面積之顯示面板驅動電路」發明專利(下稱系爭發明專利)，爰向智慧財產權法院起訴請求格科微與力晶公司應連帶賠償新臺幣 2,000 萬元，且不得製造特定型號之顯示驅動 IC 以及侵害系爭發明專利之產品，前揭產品應回收並銷毀。本案目前尚於智慧財產法院一審審理中。另，矽創公司同時聲請暫時狀態假處分，請求法院命令力晶公司於判決確定前不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口特定型號之顯示驅動 IC 及具該等顯示驅動 IC 之晶圓，以及任何侵害系爭發明專利之產品，智慧財產法院於 107 年 11 月 28 日駁回矽創公司之聲請，經矽創公司提起抗告、再抗告，嗣經最高法院於 109 年 3 月 12 日駁回矽創公司之再抗告確定。力晶公司雖有上開訴訟，惟力晶公司業已委任律師處理本案，且本案為力晶公司本身之訴訟，與力積電公司無涉，故本案訴訟結果亦尚不致對力積電公司之財務、業務生重大影響。

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，上開案件屬於力晶科技股份有限公司之訴訟案件，與該公司無涉，故上開案件之訴訟結果均不致對該公司之財務、業務產生重大影響。

五、重大勞資糾紛或污染環境事件

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，查閱該公司與主管機關之往來函文，發函勞動部、勞動部職業安全衛生署、科技部新竹科學園區管理局、勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署、新竹市政府環境保護局與苗栗縣政府環境保護局等相關業務主管機關，另並取得該公司出具之聲明書，該公司截至評估報告出具日止，尚無有重大勞資糾紛或污染環境事件。

六、是否遇有證券交易法第 156 條第 1 項第 1 款至第 3 款所列之情事。

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並核閱該公司與主管機關往來函文及取得相關聲明書，該公司最近三年度及申請年度截至出具意見書日止，並無證券交易法第 156 條第 1 項第 1 款至第 3 款所列之情事

綜上所述，該公司及其現任董事、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人於法令遵循方面，尚無對該公司之營運產生重大不利影響之情事。

柒、列明本國發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見；列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見。

一、列明本國發行公司有無「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之評估意見

經查核該公司及其子公司並無臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第九條第一項各款所列不宜上市情事，詳細評估說明，請參閱附件一。

二、列明發行公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見。

(一)獨立董事

該公司及其子公司董事會共設置九席董事，其中林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘五席為獨立董事，而獨立董事中葉疏、張嘉臨為會計或財務專業人士。茲就獨立董事符合資格條件之評估，簡要說明如下：

1.該公司及其子公司獨立董事林本堅先生，最高學歷為美國俄亥俄州立大學電機工程學系博士，自民國 89 年起至 104 年任職台灣積體電路製造股份有限公司，從研發副總經理一職退休，於台積電任職 15 年，主要負責微影部門，現為國立清華大學特聘研究講座教授及台積電聯合研發中心主任，已具備五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

2.該公司及其子公司獨立董事葉疏先生，最高學歷為美國加州大學洛杉磯分校會計學博士，自民國 82 年 2 月起至今擔任國立台灣大學會計系教授，已具備五年以上工作經驗，為商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。

3.該公司及其子公司獨立董事張嘉臨先生，最高學歷為美國普林斯頓大學電機工程博士，自民國 101 年至 105 年擔任宏達國際電子股份有限公司財務長，已具備五年以上具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

4.該公司及其子公司獨立董事吳重雨先生，最高學歷為國立交通大學電子工程博士，自民國 96 年 2 月至 100 年 1 月擔任國立交通大學校長，109 年 8 月至今擔任晶神醫創股份有限公司董事長兼技術長，104 年 6 月至 109 年 8 月擔任晶炎科技股份有限公司獨立董事，已具備五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上，及公司業務所需之工作經驗。

5.該公司及其子公司獨立董事林憲銘先生，最高學歷為國立交通大學電子計算機與控制工程學士，自民國 90 年 5 月至今擔任緯創資通股份有限公司董事長暨策略長，已具備五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

綜上，該公司及其子公司獨立董事均具有五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，另選任前二年及任職期間並無違反獨立性之情形(請參閱附件一第九款之評估)，其資格條件均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之相關規範。

另經查閱該公司董事會議事錄並實地觀察該公司董事會運作情形，獨立董事出席董事會與參與議案討論及表決情形，尚未發現重大異常之情事，且獨立董事就其來自產業、學界的專業能力及超然獨立之立場，對於該公司營運及董事會運作提供實質助益，其職權行使及相關事項皆符合該公司「獨立董事之職責範疇規則」及公開發行公司董事會議事辦法及相關法令之規定辦理，有效發揮公司治理功能。

(二)薪資報酬委員會

該公司及其子公司係於 109 年 11 月 24 日經董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並訂定薪資報酬委員會組織規程，截至評估報告出具日止，該公司及其子公司董事會委任張嘉臨、吳重雨及林憲銘等三名獨立董事擔任薪資報酬委員會之成員。經本承銷商檢視該公司及其子公司薪資報酬委員會成員之學經歷資料，其委員會之成員組成尚屬健全，並符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」所訂之資格要件，故其所召集之會議應屬有效。另經取得薪資報酬委員會之會議記錄，該公司及其子公司薪資報酬委員會應屬有效運作，且提交至董事會之建議尚屬合理，董事會就薪資報酬委員會所提之建議事項均經充分討論後進行決議。綜上所述，該公司及其子公司設置之薪資報酬委員會，已依我國證券法令規定辦理。

綜上，該公司及其子公司設置之獨立董事及薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項均依我國證券法令規定辦理。

捌、評估是否符合特定行業或組織型態公司之上市規定

一、評估是否符合集團企業申請股票上市之規定

(一)集團企業認定標準

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第六條之規定，所稱「集團企業」係指於申請上市會計年度及其最近一個會計年度內，與申請公司彼此間具有控制或從屬關係之企業整體。其具體認定標準如下：

1.具有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係：

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	說明
1.屬於母公司及其所有子公司關係者。	1.力晶科技 2. Global Powertec 3. PowerMemory 4. Maxram 5.世仁投資 6.力信投資 7.富碩投資 8.智典公司	1.母公司 經取具該公司之公開說明書，及查閱 109 年度及 110 年第一季經會計師查核或簽證之財務報告，力晶科技(股)公司(以下簡稱力晶科技)於 109 年 6 月 24 日股東會決議通過辦理減資，並以持有之該公司股票抵充應退還之減資股款，持股自 87.12%下降至 26.82%，力晶科技雖為該公司及其子公司之單一最大股東，惟力晶科技未持有該公司及其子公司之半數以上董事席次，亦無直接或間接控制其人事、財務及業務，故轉列採權益法之投資，並自該日終止將其編入合併報表編製主體。 2.子公司 經查閱該公司 109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司直接及間接持股達 50%以上之子公司計有 Global Powertec、PowerMemory 及 Maxram，計有 3 家。 3.另，取得力晶科技 109 年度經會計師查核簽證之財務報告，列入合併財務報告之子公司，包括：世仁投資(股)公司(以下

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	說明
		簡稱世仁投資)、力信投資(股)公司(以下簡稱力信投資)、富碩投資(股)公司(以下簡稱富碩投資)及智典國際(股)公司(以下簡稱智典公司)，計有 4 家。
2.申請公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者；或他公司直接或間接控制申請公司之人事、財務或業務經營者。所稱直接或間接控制其人事、財務或業務經營係指符合下列情事之一者：		該公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者；或他公司直接或間接控制該公司之人事、財務或業務經營者，計有三家，說明如下：
(1)取得對方過半數之董事席位者。	1. Global Powertec 2. PowerMemory 3. Maxram	經查閱該公司最近期經濟部變更登記表，並無他公司取得該公司過半數董事席位之情形；另經查閱該公司各轉投資事業之董事名單，該公司取得他公司過半數之董事席位，計有左列 3 家公司。
(2)指派人員獲聘為對方總經理者。	無	經詢問該公司管理階層並檢視各轉投資事業之登記資料，該公司之總經理非由他公司所派任。
(3)依合資經營契約規定擁有對方經營權者。	無	經查閱該公司 109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並檢視與他公司所簽訂之重要契約，尚未發現有依合資經營契約規定擁有對方經營權或他公司擁有該公司經營權之情事。
(4)為對方資金融通金額達對方總資產之三分之一以上者。	無	經查閱該公司 109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄及公開資訊觀測站資料，該公司並無為他公司資金融通金額達他公司總資產之三分之一

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	說明
		以上，或他公司資金融通金額達該公司總資產之三分之一以上之情事。
(5)為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上者。	無	經查閱該公司 109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄及公開資訊觀測站資料，該公司並無為他公司背書保證金額達他公司總資產之三分之一以上，或他公司背書保證金額達該公司總資產之三分之一以上之情事。
3.申請公司與他公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一以上者，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者。	無	經查閱該公司 109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、股東名冊及董事會議事錄，該公司並無與他公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一以上，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營之情事。

2.申請公司與他公司間有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係。但申請公司檢具相關事證，證明無控制或從屬關係者，不在此限：

審查認定標準	符合集團企業規範之公司	評估說明
(1)申請公司與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同者。其計算方式包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。	無	經查閱該公司董事及總經理之親屬圖及轉投資明細，並未發現該公司董事、總經理及其配偶、子女及具二親等以內之親屬擔任他公司董事、監察人及總經理合計達半數以上相同者。
(2)申請公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者。	無	經查閱該公司股東名冊、董事、總經理之轉投資明細，該公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，並無均有半數以上為相同之股東持有或出資者。
(3)對申請公司採權益法評價之他投資公司與其關係人總計持有申請公司超過半數之已發行有表決權股份者；或申請公司與其關係人總計持有申請公司採權益法評價之他投資公司超過半數之已發行有表決權股份者。	1. Global Powertec 2. PowerMemory 3. Maxram	(1)經查閱該公司 109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、公開說明書，力晶科技自 109 年 6 月 24 日股東會決議通過辦理減資，致對該公司持股降為 26.82%，採權益法評價，然經查力晶科技及其子公司、董監事等關係人合計對該公司並無持有超過半數之已發行有表決權股份之情事。 (2)經查閱該公司 109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、股東會年報關係企業資料及該公司各轉投資事業股東名冊，該公司直接或間接持股採權益法評價之轉投資公司計有左列 3 家公司。

綜上評估，符合集團企業認定標準者計有力晶科技、Global Powertec、

PowerMemory、Maxram、世仁投資、力信投資、富碩投資及智典公司，共 8 家公司。

(二)集團企業應符合事項評估

1.依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十八條之規定，集團企業中之發行公司申請股票上市，除公營事業外，雖合於本準則有關規定，但不能符合下列各款情事者，應不同意其股票上市：

(1)申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或主要商品，無相互競爭之情形，但申請公司具獨立經營決策能力者，不在此限。

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，其符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定第六條」共 8 家集團企業公司，茲將該公司與同屬集團企業公司之主要業務或主要商品列示如下，並說明有無相互競爭之情形：

A.該公司之母公司及其子公司(不含該公司及其子公司)

經查詢力晶科技 109 年度經會計師查核簽證財務報告、經濟部商工登記公示資料，其主要經營業務項目列示如下：

集團企業名稱	主要營運項目	有無相互競爭
力晶科技	108 年 5 月力晶科技將旗下的 12 吋晶圓代工相關營業、資產讓與予該公司及其子公司，轉為控股公司。	無
世仁投資	各項投資業務	無
力信投資	各項投資業務	無
富碩投資	各項投資業務	無
智典公司	藝術品買賣等業務	無

力晶科技原所營項目為 12 吋晶圓代工業務，108 年 5 月力晶科技將旗下的 12 吋晶圓代工相關營業、資產讓與予該公司及其子公司，轉為控股公司。其旗下之子公司世仁投資、力信投資及智典公司均為投資公司，智典公司主要所營項目為藝術品買賣等業務。該公司與上述集團企業所營業務並不相同，故應無相互競爭之疑慮。

B.該公司之子公司

集團企業名稱	主要營運項目	有無相互競爭
Global Powertec	投資控股公司	無
PowerMemory	Flash 製程相關設計及研發	無
Maxram	DRAM 製程相關設計及研發	無

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司屬半導體產業，主要從事邏輯暨特殊應用產品之晶圓代工服務及記憶體產品之晶圓代工服務。上表集團企業中，該公司透過境外設立投資控股公司 Global Powertec，轉投資二家日本公司 PowerMemory 及 Maxram，主係為配合力積電營運需求，從事研發專案以賺取技術服務收入，主要營業項目分別為 Flash 及 DRAM 製程相關設計及研發。該公司對所有轉投資事業之財務業務具有完全之控制能力，且該公司及其轉投資事業之業務運作係由該公司統籌規劃集團資源之運用與分工，就企業型態而言，並無相互競爭情形。

綜上所述，該公司與上述 8 家集團企業公司之主要業務或產品並無相互競爭之情形。

(2)申請公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，除各應就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，並經董事會通過外，應各出具書面聲明或承諾無非常規交易情事；無業務往來者，應由申請公司出具書面，承諾日後有往來時必無非常規交易之情事。

該公司與同屬集團企業公司間之財務業務往來皆已訂定相關書面規章，並經董事會決議通過。此外，該公司與有財務業務往來之集團企業公司，雙方均已出具財務業務往來無非常規交易情事之書面聲明，而針對無財務業務往來之集團企業公司，亦已出具日後有往來時必無非常規交易情事之書面承諾。

(3)其財務業務狀況及前述之作業辦法與其他同業比較應無重大異常現象。

該公司之「關係企業相互間財務業務相關作業規範」除依主管機關之有關規定修訂，係考量本身業務經營狀況，並參酌業界已制定之辦法修訂完成，應無重大異常之情事。

(4)其對於銷售予集團企業公司之產品，應具有獨立行銷之開發潛力。

經檢視該公司及其子公司 109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無銷售產品予集團企業公司之情事。該公司主導企業經營方針及營運策略，並統籌各子公司之客戶開發、產品研發、經營決策及市場行銷等，故該公司應具有獨立行銷之開發潛力。

(5)申請上市時，最近期及最近一個會計年度來自集團企業公司之進貨金額未超過百分之七十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，得不適用之。

經檢視該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證之財務報告，該公司最近期及最近二個會計年度之進貨金額並無來自集團企業公司超過百分之七十之情事。

(6)申請上市時，最近期及最近一個會計年度來自集團企業公司之營業收入或營業利益金額未超過百分之五十；或利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生

營業收入金額未超過百分之五十。但基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因所造成，且前開比率未超過百分之七十者，得不適用之。

經檢視該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證之財務報告,該公司最近期及最近二個會計年度營業收入金額並無來自集團企業公司超過百分之五十亦無利用集團企業公司提供之關鍵性技術或資產所生營業收入超過百分之五十之情事。

2.依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十九條之規定，申請時屬於母子公司關係之子公司申請其股票上市，除公營事業外，雖合於「臺灣證券交易所股份有限公司上市審查準則」有關規定，但不能符合下列各款情事者，應不同意其股票上市：

該公司及其子公司非屬於母子公司關係之子公司申請其股票上市,故不適用本項評估。

(三)集團企業評估結論

依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」,所列各項具體認定標準逐項評估後，該公司及其子公司應無違反集團企業申請股票上市規定之情事。

二、評估是否符合建設公司申請股票上市有關規定評估

該公司及其子公司非屬建設公司，故不適用本項評估。

三、評估是否符合投資控股公司、金融控股公司或其他特定組織型態公司申請上市之有關規定

該公司及其子公司非屬投資控股公司、金融控股公司或其他特定組織型態公司，故不適用本項評估。

玖、評估發行公司公司治理評鑑自評報告是否允當表達其公司治理運作情形

經檢視該公司出具之公司治理評鑑自評報告，其公司治理評鑑之自評業依自評報告所列各評量指標評估，包括股東權益、董事會職能、審計委員會及薪資報酬委員會職能、資訊透明度、內控內稽制度、經營策略及利害關係人與社會責任等項目，經本證券承銷商逐條核閱該公司各評量指標之自我評估結果，該公司之公司治理評鑑自評報告係已敘明其目前實際運作情形，並符合相關法規制定，確實遵循辦理，綜上所述，該公司之公司治理評鑑自評報告尚足以允當表達公司治理目前運作情形。

拾、對上列各項目有關證券承銷商評估報告完成日起，截至股票上市契約生效日之前一日止之期後事項，應隨時加以更新說明與評估；於股票上市用公開說明書刊印日前，如有重大期後事項，亦應加以更新說明與評估。

該公司及其子公司截至評估報告出具日止，尚無上述所列之情事。

拾壹、以投資控股公司或金融控股公司申請股票上市者，承銷商應就被控股公司或其子公司之所營事業性質，依第四、五、六、八、九、十一及十二條等規定進行評估，出具各被控股公司或子公司之審查意見，再憑以出具綜合彙總意見。

該公司及其子公司非投資控股公司或金融控股公司，故不適用。

拾貳、本國上市（櫃）公司之海外子公司申請其股票第一上市者，承銷商應評估本國上市（櫃）公司決策過程之適法性、對其營運及財務狀況是否有重大不利之影響，及擬採行之因應措施。

該公司及其子公司非屬本國上市(櫃)公司之海外子公司申請其股票第一上市，故不適用本項之評估。

拾參、其他補充揭露事項

無。

附件、依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第九條第一項各款所列不宜上市情事之承銷商審查意見

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
一、遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款、第二款所列情事，或其行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。		是	
(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。	(一)經參閱該公司及其子公司 107 年度迄今之董事會及股東會議事錄、與主管機關往來函文、107~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告以及該公司及其子公司出具之聲明書，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師所出具之法律意見書，該公司及其子公司截至評估報告出具日止，尚無遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞。		
(二)發行該有價證券之公司，遇有重大災害,簽訂重要契約,發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更。	(二)經參閱該公司及其子公司 107 年度迄今之董事會及股東會議事錄、與主管機關往來函文、目前存續有效之重要契約、107~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並取得票據交換所之退票紀錄查詢資料及該公司及其子公司出具之聲明書，另參酌翰辰法律事務所邱雅文律師所出具之法律意見書，該公司及其子公司截至評估報告出具日止，並無遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計劃之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。		
(三)發行該有價證券公司之行為有虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。	(三)經參閱該公司及其子公司 107 年度迄今之董事會及股東會議事錄、與主管機關往來函文、107~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告以及該公司及其子公司出具之聲明書，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師所出具之法律意見書，截至評估報告出具日止，該公司及其子公司尚無虛偽不實或違法情事，足以影響其上市後之證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
	綜上所述，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至評估報告出具日止，尚無遇有證券交易法第一百五十六條第一項第一款至第三款所列之情事。		
二、財務或業務未能與他人獨立劃分者。		是	
(一)資金來源過度集中於非金融機構者。	(一)經核閱該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證之財務報告、相關明細帳帳冊，訪談財務主管及取得該公司及其子公司出具之聲明書，該公司及其子公司向非金融機構之借款已清償，截至評估報告出具日止並無資金來源過度集中於非金融機構之情事。		
(二)申請公司與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之虞者。	(二)經核閱該公司及其子公司現行存續有效之重要契約及取具該公司及其子公司出具之聲明書，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，尚無發現該公司及其子公司有與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之虞之情事。		
(三)與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分者。但母子公司間共用貸款額度，不在此限。	(三)經核閱該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證之財務報告、該公司及其子公司現行有效之銀行借款合約、函詢銀行之回函、取得該公司及其子公司出具之聲明書等資料及訪談公司人員，該公司及其子公司並無與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分之情事。 綜上所述，該公司及其子公司並無財務或業務未能與他人獨立劃分之情事。		
三、有足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛或污染環境情事，尚未改善者。		是	
(一)所規定「足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛」，係指下列情事之一：	(一)「足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛」評估：		
1.發生重大勞資爭議者。	1.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文、營業外收支明細帳、會計師查核簽證或核閱之財務報告，並函詢相關主管機關、抽核薪資循環及勞資會議紀錄、訪談該公司管理階層與員工，另取得		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
	該公司及其子公司出具之聲明書及參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書等，該公司及其子公司尚無發生足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資爭議情事。		
2.未依法提撥職工福利金，組織職工福利委員會者；或未依法按月提撥勞工退休準備金專戶儲存、未依法補提勞工退休準備金差額或未依法提繳勞工退休金者。	2.經取得該公司設立職工福利委員會之登記證及組織章程，該公司已依法組織職工福利委員會，並設置專戶儲存且按月提撥職工福利金，此外，該公司已依勞工退休金條例提繳勞工退休金，經抽核該公司職工福利金及退休金提撥情形，其相關憑證、金額、作業程序及帳務處理皆依規定辦理。		
3.因安全衛生設施不良而發生重大職業災害；或違反勞工安全衛生法被處以部分或全部停工者；或設置危險性機械、設備未檢查合格者。但經申請由檢查機構複查合格者，不在此限。	3.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年迄今與主管機關往來函文，取得該公司及其子公司出具之聲明書、函詢勞動部、勞動部職業安全衛生署及科技部新竹科學園區管理局，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，該公司及其子公司最近三年度及申請上市年度截至評估報告出具日止，並無因安全衛生設施不良而發生重大職業災害；或違反勞工安全衛生法被處以部分或全部停工者；或設置危險性機械、設備未檢查合格之情事。		
4.積欠勞工保險保費及滯納金，經依法追訴仍未繳納者。	4.經查閱該公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文、抽核該公司勞工保險費及健保費繳納情形、函詢勞動部勞工保險局及衛生福利部中央健康保險署，截至評估報告出具日止，該公司並無積欠勞保費、健保費及滯納金之情事。		
(二)所規定「足以影響財務業務正常營運之重大環境污染」，係指公司或其事業活動相關場廠有下列情事之一：	(二)「足以影響財務業務正常營運之重大環境污染」評估：		
1.依法令應取得污染設置、操作或排放許可證而未取得者。	1.經查閱107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文及營業外收支明細帳、詢問該公司管理當局及取得該公司及其子公司出具之聲明書等，該公司及其子公司未有應取得污染設置、操作或排放許可證而未取得者。		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
2.曾因環境污染,於申請上市會計年度或最近二會計年度,各該年度經環保機關按日連續處罰者或經限期改善,而未完成改善者。	2.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文及營業外收支明細帳、107~109年度及110年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、取得該公司及其子公司出具之聲明書以及函詢新竹市政府、苗栗縣政府環境保護局及科技部新竹科學園區管理局，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，截至評估報告出具日止，該公司及其子公司並無因環境污染，於申請上市會計年度或最近二會計年度受環保機關按日連續處罰，或經限期改善而未完成改善之情事。		
3.有公害糾紛事件而無有效污染設備,或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄者。	3.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文及營業外收支明細帳、107~109年度及110年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、搜尋報章雜誌等媒體資訊、並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書及取得該公司及其子公司出具之聲明書，尚無發現該公司及其子公司有公害糾紛事件而無有效污染防治設備，或未能提供污染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄之情形。		
4.有環境污染情事,經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證者。	4.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文及營業外收支明細帳、107~109年度及110年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、函詢新竹市政府、苗栗縣政府環境保護局及科技部新竹科學園區管理局，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書及取得該公司及其子公司出具之聲明書，尚未發現該公司及其子公司有因污染環境經相關機關命令停工、停業、歇業或撤銷污染相關許可證之情形。		
5.廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中造成環境重大污染,因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病者。	5.經詢問該公司管理當局、查閱該公司及其子公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文、搜尋報章雜誌等媒體資訊、參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書、函詢環境保護主管機關及取得該公司出具之聲明書，該公司及其子公司並無廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或於處理過程中		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
	造成環境重大污染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病之情事。		
6.經中央主管機關指定公告之事業,其土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址者。	6.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文、參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書、函詢環境保護主管機關並取得該公司出具之聲明書，該公司及其子公司非屬於中央主管機關指定公告之事業，無土地因污染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址之情事。		
7.法人有製造、加工或輸入偽禁環境用藥情事,其負責人經判刑確定者。	7.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文、搜尋報章雜誌等媒體資訊、參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書、函詢環境保護主管機關並取得該公司出具之聲明書，該公司及其子公司並無因製造、加工、或輸入偽禁環境用藥情事，而其負責人經判刑確定之情形。		
(三)所規定「尚未改善者」,係指在本公司受理其股票上市申請案之日以後仍有上開情事者。	(三)該公司及其子公司尚無左列情事之適用。		
(四)但前(二)第 2 款之重大環境污染情事，以其已委託經環保機關認可之檢測機構，進行檢測及提出檢測結果報告書，並據以向環保機關申報污染改善完成報告書，於申報後三個月內未再續遭處罰者，作為是否改善之認定標準。	(四)該公司及其子公司尚無左列情事之適用。 綜上評估，截至評估報告出具日止，該公司及其子公司並無發生足以影響其財務業務正常營運之重大勞資糾紛或重大環境污染情事而尚未改善之情事。		
四、經發現有重大非常規交易，尚未改善者。		是	
(一)所規定「重大非常規交易」,係指申請公司有下列各款情事之一者，但公營事業依審	(一)該公司並無重大非常規交易，尚未改善者，其評估如下所述：		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
計法規辦理者，不在此限：			
1.進銷貨交易之目的、價格及條件，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理者。	1.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年第一季經會計師查核簽證之財務報告，並抽核最近三年度及申請年度該公司前十大進銷貨廠商客戶之相關進銷貨往來情形，並無進銷貨交易之目的、價格、條件及其交易之處理程序，與一般正常交易顯不相當或顯欠合理者。		
2.依主管機關訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，應行公告及申報之取得或處分資產交易行為，未能合理證明其內部決定過程之合法性，或其交易之必要性，或其有關報表揭露之充分性，暨價格與款項收付情形之合理性者。	2.經檢視該公司「取得或處分資產處理程序」，已依主管機關之規定辦理，並經審計委員會、董事會通過後，提報股東會同意。經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年第一季經會計師查核簽證之財務報告、董事會議事錄、固定資產清冊、取得及處分資產彙總表及抽核相關文件，該公司於108年12月6日至109年6月9日及109年10月12日後為公開發行，其重大資產交易尚依「公開發行公司取得或處分資產處理程序」辦理公告及申報，尚無發現重大異常情事。其內部決定過程之合法性、交易之必要性、有關報表揭露之充分性，暨價格與款項收付情形，尚無重大異常或不合理之情形。		
3.以簽約日為計算基準，其最近五年內買賣不動產有下列情形之一者：			
(1)向關係人購買不動產，其按主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條所列方法，評估不動產成本結果，均較實際交易價格為低，且未符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定者。	(1)經參閱該公司及子公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司及子公司經會計師查核簽證之財務報告，該公司最近五年度及申請年度截至評估報告刊印日止並無向關係人買賣不動產之情事，故無左列非常規交易之情事。		
(2)出售不動產予關係人，其按主管機關所訂頒「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條所列方法，評估不動產成本結	(2)經參閱該公司及其子公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司及其子公司經會計師查核簽證之財務報告，該公司及其子公司最近五年度及申請年度截至評估報告刊印日止並無向關係人買賣不動產之情事，故無左列		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
果，均較實際交易價格為高者。	非常規交易之情事。		
(3)向關係人買賣不動產，收付款條件明顯異於一般交易，而未有適當理由者。	(3)經參閱該公司及其子公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司及其子公司經會計師查核簽證之財務報告，該公司及其子公司最近五年度及申請年度截至評估報告刊印日止並無向關係人買賣不動產之情事，故無左列非常規交易之情事。		
(4)申請公司所買賣土地與關係人於相近時期買賣鄰近土地，價格有明顯差異而未有適當理由者。	(4)經參閱該公司及其子公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司及其子公司經會計師查核簽證之財務報告，該公司及其子公司最近五年度及申請年度截至評估報告刊印日止並無向關係人買賣不動產之情事，故無左列非常規交易之情事。		
(5)最近五個會計年度末一季銷貨或租賃不動產予關係人所產生之營業收入，逾年度營業收入百分之二十，而未有適當理由者。	(5)經參閱該公司及其子公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司及其子公司經會計師查核簽證之財務報告，該公司及其子公司最近五年度及申請年度截至評估報告刊印日止並無向關係人買賣不動產之情事，故無左列非常規交易之情事。		
(6)向非關係人買賣不動產，有其他資料顯示買賣不動產交易明顯異於一般交易而無適當理由者。	(6)經參閱該公司及其子公司董事會議事錄、財產目錄、明細帳等帳冊及該公司及其子公司經會計師查核簽證之財務報告，該公司及其子公司最近五年度及申請年度截至評估報告刊印日止向非關係人購買不動產，係有向新日光能源科技股份有限公司取得建物及附屬設施，經取得京瑞不動產估價師聯合事務所及宸輝不動產估價師聯合事務所出具之估價報告，其向非關係人買賣金額，與其他資料顯示買賣不動產交易，並無明顯異於一般交易，應無重大異常或不合理之情形。		
4.非因公司間業務交易行為有融通資金之必要,將大量資金貸與他人者。	4.經查閱該公司及其子公司107~109年度及110年第一季經會計師查核簽證之財務報告及明細帳，並未發現有非因公司間業務交易行為有融通資金之必要，而仍資金貸與他人之情事。		
5.前項第三款關於向關係人買	5.經查核該公司及其子公司最近五年度及申請年度		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
賣不動產之規定,對於最近五年內其交易對象之前手或前前手有關係人身分時,亦應比照適用之。但買賣不動產之交易，其交易對象簽約取得時間,至本次交易簽約日止超過五年者，可免適用之。	截至評估報告刊印日止並無向關係人買賣不動產之情事，故不適用。		
6.申請公司有第一項所定情事,致獲得利益者,經將所獲得利益予以扣除設算後,其獲利能力仍應符合上市條件。	6.經查核該公司及其子公司並無重大非常規交易，故不適用。		
(二)所規定「尚未改善」,其改善之認定，係指符合下列各款情事之一者：	(二)經查核該公司及其子公司並無重大非常規交易，故不適用。		
1.因非常規交易而致申請公司以外之人獲得利益者,該獲得利益之人已將所得利益歸還應得之人者。			
2.該非常規交易行為經檢調或司法單位確定無犯罪情事。			
3.該非常規交易已恢復原狀者。	綜上評估,該公司及其子公司並無重大非常規交易迄申請時尚未改善之情事。		
五、申請上市年度已辦理及辦理中之增資發行新股併入各年度之決算實收資本額計算，不符合上市規定條件者。	該公司業於 110 年 7 月 12 日取得經臺灣證券交易所函轉經濟部工業局核可之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書」,故其係以科技事業申請股票上市，遂依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 5 條規定，逐項評估科技事業申請股票上市資格條件，經查核該公司業已符合以科技事業申請上市之資格條件。	是	
六、有迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度，或不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告等情事，情節重大者。		是	
(一)所規定「不依有關法令及一	(一)是否不依有關法令及一般公認會計原則編製財務		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
般公認會計原則編製」	報告之評估如下：		
1.財務報告未依有關法令及一般公認會計原則編製，經會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書者，或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告之允當表達者。	1.經查閱該公司107~109年度及110年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，除110年第一季因非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱而有保留意見，惟對財務報告之允當表達並無影響，其餘年度均係出具無保留意見之查核報告；該公司編製之財務報告均依證券發行人財務報告編製準則及國際會計原則編製，尚無會計師出具否定意見或無法表示意見之情事，其財務報告應屬允當表達。		
2.財務報告經主管機關函示應改進而未改進者。	2.經查閱該公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關往來函文，並無財務報告經主管機關函示應改進而未改進之情事。		
3.簽證會計師查核工作底稿，經本公司調閱後，發現有重大缺失，致無法確認財務報告是否允當表達者。	3.經核閱107~109年度及110年第一季會計師查核簽證或核閱財務報告之工作底稿，並未發現有重大缺失，致無法確認財務報告是否允當表達之情事。		
(二)所規定「迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度」，係指有下列情事之一者：	(二)是否有迄未有效執行書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度之評估如下：		
1.在申請上市年度未依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則或內部控制相關法令規定，建立健全書面會計制度。	1.經查閱該公司之書面會計制度、內部控制制度，該公司及其子公司已依「證券發行人財務報告編製準則」規定，建立健全書面會計制度。另其內部控制制度及內部稽核制度亦已依該公司管理及業務發展所需，配合相關法令制定，並經該公司及其子公司董事會通過。		
2.經本公司實地查核，發現未依書面會計制度、內部控制制度、內部稽核制度合理運作者。	2.經核閱該公司及其子公司107~109年度會計師出具之內部控制建議書，並未發現有重大缺失；另該公司及其子公司業已依規定委請會計師就其內部控制制度之設計與實際運作情形進行專案審查，會計師於110年7月20日出具無保留意見之內部控制制度專案審查報告，該公司及其子公司內部控制制度之設計及執行均屬有效。 綜上所述，該公司及其子公司已依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告，且內部控制、內部稽核及書		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
	面會計制度等亦已建立且有效執行。		
七、所營事業嚴重衰退者。 (一)所規定「嚴重衰退」，係指有下列情事之一者： 1.最近一個會計年度或申請上市會計年度之營業收入及營業利益與同業比較，顯有重大衰退者。 2.最近一個會計年度或申請上市會計年度之稅前淨利與同業比較，顯有重大衰退者。 3.最近三個會計年度之營業收入及營業利益，均連續呈現負成長情形者。 4.最近三個會計年度之稅前淨利，連續呈現負成長情形者。 5.產品或技術已過時，而未有改善計畫者。	(一)依本款(二)之規定，該公司 109 年度之營業利益及稅前淨利占股本比率分別為 18.50%及 15.45%，皆已超過 12%，故不適用本項之評估。	是	
(二)前項規定，對於申請股票上市公司最近一個會計年度之營業利益及稅前淨利占股本比率不低於百分之十二者，不適用之。 第一項第一、二款所規定「同業比較」，證券承銷商應評估說明所採樣同業之合理性。	(二)該公司 109 年度之營業利益及稅前淨利占股本比率皆已超過 12%，故不適用本項之評估。		
(三)第一項第三、四款之規定，對於已有具體改善計畫並產生效益者，不適用。	(三)該公司無前述(一)三、四款之情事。 綜上評估，該公司所營事業並無嚴重衰退之情事。		
八、申請公司於最近五年內，或其現任董事、總經理或實質負責人於最近三年內，有違反誠信原則之行為者。		是	

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
(一)公司部分 1.所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經清償贖回註記者。	(一)公司部分 1.經取得該公司台灣票據交換所第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心之信用報告及參酌翰辰法律事務所邱雅文律師之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無所開立之支票存款戶經票據交換所公告為拒絕往來戶或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入紀錄未經清償贖回註記之情事。		
2.向金融機構貸款有逾期還款之情形者。但還款完畢已逾三年者，不在此限。	2.經取得財團法人金融聯合徵信中心之信用報告，參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，函詢該公司主要往來銀行並取得該公司出具之聲明書，該公司並無向金融機構貸款而有逾期還款之情事。		
3.違反勞動基準法被處以刑罰確定者，但最近二年內經檢查機構複查已改善者，不在此限。	3.經詢問該公司管理當局，查閱該公司與主管機關往來函文，參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無違反勞動基準法被處以刑罰確定且尚未改善之情事。		
4.違反稅捐稽徵法經判決有罪確定者。	4.經取具國稅局及稅捐稽徵機關出具之無違章欠稅紀錄回覆函、檢視該公司與主管機關往來函文及核閱該公司相關明細帳冊，參閱翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無因違反稅捐稽徵法，而經判決有罪確定之情事。		
5.違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項者。	5.經參閱翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並取得該公司出具之聲明書，該公司並無違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項。		
6.有其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信情事，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益者。	6.經核閱該公司董事會及股東會會議記錄，並參閱翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書及取得該公司出具之聲明書，截至目前為止，該公司並無其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益之情事。		
(二)董事、監察人、總經理或實質負責人部分	(二)董事、總經理或實質負責人部分(該公司已設置審計委員會，故無監察人)		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
1.同前款第1、2、3、4及5目。但屬向金融機構貸款逾期還款者,倘逾期還款情節非屬重大或有合理事由者，不在此限。	1.經取得該公司董事及總經理出具之聲明書、台灣票據交換所第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心查詢之信用報告資料、國稅局與稅捐稽徵機關所出具之無違章欠稅記錄之回覆函及參閱翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書,該公司董事有下列情事:(一) 董事長黃崇仁108年度綜合所得稅經國稅局核定有一筆利息收入,核定應補繳稅額新臺幣36,099元,係董事長黃崇仁於104年借款予他人,惟借款人至今並未償還本金及利息故並無利息收入，董事長黃崇仁並已向國稅局申請更正。(二) 董事邵章榮108年度綜合所得稅經國稅局核定有一筆租賃收入，核定應補繳稅額新臺幣32,499元，邵章榮董事並無國稅局所核定之租稅收入並已向國稅局申請更正。上述情事，目前尚於國稅局審理中，最終若認定須繳稅，僅需繳款並不會有違反稅捐稽徵法之情事。該公司董事及總經理並無開立票據經票據交換所公告為拒絕往來戶或發生存款不足而退票、向金融機構貸款有逾期還款、違反勞動基準法被處以刑罰、違反稅捐稽徵法經判決有罪及違反申請上市時所出具聲明書之聲明事項等之情事。		
2.犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法、票券金融管理法等商事法規定之罪，或犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。	2.經取得該公司董事及總經理所出具之聲明書、查詢法源法律網之裁判書及參閱翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，該公司董事或總經理並無因違反左列法令，而經法院判決有期徒刑以上之刑者。		
3.有經營其他公司涉及惡性倒閉等不良經營行為者。	3.經取得該公司董事及總經理所出具之聲明書，並參閱翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，該公司董事及總經理並無經營其他公司涉及惡性倒閉等不良經營之行為。		
4.有其他重大違反法令或誠實信用原則之行為者。	4.經取得該公司董事及總經理所出具之聲明書，並參閱翰辰法律事務所邱雅文律師所出具之法律意見書，該公司董事有下列情事:董事長黃崇仁先生，於民國2005、2006年間擔任力晶半導體股份有限公司(力晶科技股份公司前名稱，下稱力晶公司		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
	)董事長時，因董事長職業關係獲悉力晶公司與旺宏電子股份有限公司(下稱旺宏公司)間「買賣晶圓三廠廠房」與「策略聯盟」之重大消息，卻於該消息於2006年1月18日公開前即利用力晶集團證券帳戶購買旺宏公司股票，遭投保中心請求侵權行為的損害賠償案，經最高法院駁回上訴後，高等法院裁定支付賠償款新臺幣463仟元，並無有期徒刑以上之罪。上開訴訟案件之原因係發生於94、95年間，經最高法院102年台上字第1672號刑事判決原判決關於黃崇仁違反證券交易法部分撤銷及最高法院104年度台上字第78號刑事判決駁回檢察官上訴後，黃崇仁先生並無刑事判決有罪定讞之情事；另投保中心求償民事案件，最終判決黃崇仁先生應給付投保中心463仟元之應給付之金額尚非重大，故本民事訴訟案件之結果應尚非重大，且黃崇仁先生已於判決確定後於107年12月27日給付判決金額，故亦無經法院判決確定須負擔損害賠償義務，卻迄未依法履行之情事。經詢問該公司相關人員並查閱該公司之公開說明書、投保中心回函，黃崇仁於上開訴訟案件之後尚無因違反證券交易法而遭起訴或遭投保中心求償，且業已參與公司治理進修以加強公司治理觀念，而黃崇仁先生最近三年度迄今並無因違反證券交易法而被判決有罪之情事。黃崇仁先生近幾年來均積極參與進修公司治理課程，且協助推動完善力積電公司自身董事會之公司治理架構，故黃崇仁先生對於善盡董事職責與對現今社會與主管機關對公司治理之期許與要求，應有忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務。 綜上所述，該公司於最近五年內及其現任董事及總經理於最近三年內，並無重大違反誠信原則之行為。		
九、申請公司之董事會成員少於五人，獨立董事人數少於三人或少於董事席次五分之一；其董事會有無法獨立執行其職務；或未依證券交易法第十四條之六及其相關規	該公司目前設有董事九席，分別為黃崇仁、謝再居、力晶科技股份有限公司(代表人：徐清祥)、仁典投資股份有限公司(代表人：邵章榮)、林本堅(獨立董事)、葉疏(獨立董事)、張嘉臨(獨立董事)、吳重雨(獨立董事)及林憲銘(獨立董事)，其中獨立董事共有五席，業已符合董事會成員至少五席，且獨立董事不得少於三席或少於	是	

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
定設置薪資報酬委員會者。另所選任獨立董事至少一人須為會計或財務專業人士。	董事席次五分之一之規定，其中獨立董事張葉疏及張嘉臨為會計或財務專業人士，亦符合左列之規定。 另該公司業已依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會，並經董事會決議委任獨立董事張嘉臨、吳重雨及林憲銘擔任薪資報酬委員會委員。		
(一)擔任申請公司獨立董事，有不符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之要件者。 1.擔任申請公司之獨立董事，應取得下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗： (1)商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。 (2)法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 (3)具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	(一)該公司係依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂之程序及要件，選任林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘等五位獨立董事，其評估說明如下所述： 1.經取得該公司獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘之學經歷資料，並分別說明如下： (1)林本堅先生最高學歷為美國俄亥俄州立大學電機工程學系博士，自民國89年起至104年任職台灣積體電路製造股份有限公司，從研發副總經理一職退休，於台積電任職15年，主要負責微影部門，現為國立清華大學特聘研究講座教授及台積電聯合研發中心主任，已具備五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 (2)葉疏先生最最高學歷為美國加州大學洛杉磯分校會計學博士，自民國82年2月起至今擔任國立台灣大學會計系教授，已具備五年以上工作經驗，為商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。 (3)張嘉臨先生最高學歷為美國普林斯頓大學電機工程博士，自民國101年至105年擔任宏達國際電子股份有限公司財務長，已具備五年以上具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 (4)吳重雨先生最高學歷為國立交通大學電子工程博士，自民國96年2月至100年1月擔任國立交通大學校長，109年8月至今擔任晶神醫創股份有限公司董事長兼技術長，104年6月至109年8月擔任晶炎科技股份有限公司獨立董事，已具備五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上，及公司業務所需		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
	之工作經驗。 (5)林憲銘先生最高學歷為國立交通大學電子計算機與控制工程學士，自民國90年5月至今擔任緯創資通股份有限公司董事長暨策略長，已具備五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 經上述評估，五位獨立董事皆符合專業資格條件及均具備五年以上工作經驗。		
2.有下列情事之一者，不得充任獨立董事，其已充任者，當然解任： (1)有公司法第三十條各款情事之一。 (2)依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。 (3)違反本辦法所定獨立董事之資格。	2.經取得該公司獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘出具之獨立性聲明書，並查詢法源法律網之裁判書及台灣票據交換所第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心出具之信用報告及無欠稅證明，並未發現該公司之五位獨立董事有公司法第三十條各款情事之一，且三位獨立董事皆以自然人身分選任，均無依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選，亦無違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所定獨立董事資格之情事。		
3.擔任申請公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間無下列情事之一：	3.茲就該公司獨立董事選任前二年及任職期間，評估是否符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項各款之獨立性規定：		
(1)公司或其關係企業之受僱人。	(1)經取得該公司出具之聲明書及取具獨立董事出具之獨立董事聲明書、學經歷資訊彙總、轉投資明細表，獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘選任前二年及任職期間未曾任職於該公司及其關係企業，故非為該公司及關係企業之受僱人。		
(2)公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)	(2)經取具該公司及其關係企業之董事、監察人名單、該公司變更登記事項及獨立董事聲明書、學經歷資訊彙總、轉投資明細表，並未發現有擔任該公司或其關係企業董事或監察人之情事。		
(3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司	(3)經取具該公司股務代理出具之聲明書、獨立董事出具之親屬表、聲明書、轉投資明細表，該		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	公司獨立董事及其配偶、未成年子女並未持有該公司已發行股份，故無左列規定之情事。		
(4)第一款所列之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	(4)經取具該公司股務代理出具之聲明書、該公司及其關係企業之董監名單、經理人名單、該公司變更登記事項卡、獨立董事出具之親屬表、聲明書、學經歷資訊彙總、轉投資明細表，申請公司獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬並非該公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，且未持有該公司已發行股份總額1%以上，亦非持股前十名之自然人股東。		
(5)直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	(5)經取具該公司股務代理出具之聲明書，並查詢持有該公司已發行股份總數百分之五、持股前五名或依公司法第27條第2項指派代表人擔任該公司董事之法人股東董監事名單、獨立董事之聲明書、獨立董事學經歷資訊彙總、轉投資明細表，及該公司出具之聲明書，該公司之獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘於選任前二年及任職期間並無左列情事。		
(6)公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	(6)經取具公司及其關係企業之董監名單，以及獨立董事張嘉臨之聲明書、獨立董事學經歷資訊彙總、轉投資明細表，該公司之獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘於選任前二年及任職期間並無左列情事。		
(7)公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他	(7)經取具獨立董事之獨立董事聲明書、獨立董事學經歷資訊彙總、轉投資明細表，他公司彙整，除該公司董事長黃崇仁有擔任他公司董事長		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	外，尚無符合其他左列之他公司或機構，另取得該公司出具之聲明書，該公司之獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘於選任前二年及任職期間並無左列情事。		
(8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。	(8)經取具該公司股務代理出具之聲明書，力晶科技股份有限公司符合特定公司認定之標準，查詢特定公司資訊，特定公司持股百分之五以上股東。取得獨立董事出具之聲明書、獨立董事學經歷資訊彙總、轉投資明細表，另取得該公司出具之聲明書，該公司之獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘於選任前二年及任職期間並無左列情事。		
(9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 申請公司之獨立董事曾任前項第二款或第八款之公司或其關係企業或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者，不適用第一項於選任前二年之規定。	(9)經取得該公司出具之聲明書及取得獨立董事之聲明書、轉投資明細表學經歷資訊彙總及親屬表，並檢視該公司及關係企業勞務費明細帳，林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘於選任前二年及任職期間並非為該公司或其關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶，故無違反左列規定。		
4.公開發行公司之獨立董事兼	4.經取得獨立董事張嘉臨之聲明書、轉投資明細表		

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家：	、學經歷資訊彙總，並未發現該公司之獨立董事有兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。		
5.公開發行公司獨立董事選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，並載明於章程，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。	5.經檢視該公司之公司章程及股東會議事錄，已明定全數董事之選舉採候選人提名制，且目前該公司獨立董事張嘉臨、吳重雨及林憲銘係於109年11月24日股東臨時會依候選人提名制度選任之，獨立董事林本堅、葉疏係於110年7月2日股東常會依候選人提名制度選任之。		
(二)擔任申請公司獨立董事者，未於該公司輔導期間進修法律、財務或會計專業知識每年達三小時以上且取得「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」參、四(一)、(二)、(四)訂定之進修體系所出具之相關證明文件。	(二)經取得該公司五位獨立董事於專業進修機構核發之研習證明，該公司之獨立董事林本堅、葉疏、張嘉臨、吳重雨及林憲銘，均已於該公司輔導期間進修法律、財務或會計專業知識每年達三小時以上，並無違反左列規定之情事。		
(三)申請公司之董事彼此間有超過半數之席次，具有下列關係之一： 1.配偶。 2.二親等以內親屬。 3.同一法人之代表人。 前項第三款之規定，對於政府或法人為股東，以政府或法人身分當選為董事，而指派代表行使職務之自然人；暨由其代表人當選為董事之代表人，亦適用之。	(三)經取得該公司董事之轉投資明細、親屬表及其所出具之聲明書等資料，該公司九席董事彼此間並無超過半數之席次具有本款所列親屬關係或同一法人之代表人者，故該公司董事尚能獨立執行其職務。 綜上評估，該公司之董事，並未有無法獨立執行其職務之情事，且該公司已依證券交易法第十四條之六及其相關規定設置薪資報酬委員會。		
十、申請公司於申請上市會計年度及其最近一個會計年度已登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票，於掛牌日起，其現任董事及持股超過其發行股份總額百分之十之股東有未於興櫃股票市場而買賣申請	該公司自109年12月9日登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票起，經查閱該公司現任董事自109年12月9日起之持股異動情形，並取得該公司現任董事所出具之聲明書及每月內部人持股異動詢問單及持股變動情形申報書，尚無發現現任董事有未於興櫃股票市場而買賣該公司發行股票之情事。	是	

項目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上市	說明
公司發行之股票情事者。但因辦理本準則第十一條之承銷事宜或有其他正當事由者，不在此限。			
十一、申請公司之股份為上市(櫃)公司持有且合於下列條件之一者，該上市(櫃)公司最近三年內為降低對申請公司之持股比例所進行之股權移轉，未採公司原有股東優先認購或其他不損害公司股東權益方式： (一)申請公司係屬上市(櫃)公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司。 (二)申請公司係屬上市(櫃)公司子公司，於申請上市前三年內，上市(櫃)公司降低對申請公司直接或間接持股比例累積達百分之二十以上。	該公司及其子公司非屬上市(櫃)公司進行分割後受讓營業或財產之既存或新設公司，亦非屬上市(櫃)公司之子公司，故不適用本項評估。	是	
十二、其他因事業範圍、性質或特殊狀況，而不宜上市之情事。	該公司及其子公司尚無其他因事業範圍、性質或特殊情況，而有不宜上市之情事。	是	

主辦證券承銷商：元大證券股份有限公司

評 估 人 簽 章 ：陳秀梅

李丕成

鍾志豪

潘信助

辜佑華

陳靜如

歐哲源

林鴻儒

單位主管簽章：江淑華

負 責 人 簽 章 ：陳修偉

中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

(限力晶積成電子製造股份有限公司申請股票初次上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：兆豐證券股份有限公司

評 估 人 簽 章 ：

單位主管簽章：

負 責 人 簽 章 ：

中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

(限力晶積成電子製造股份有限公司申請股票初次上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

評 估 人 簽 章 ：

單位主管簽章：

負 責 人 簽 章 ：

中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

(限力晶積成電子製造股份有限公司申請股票初次上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

評 估 人 簽 章：

單位主管簽章：

負 責 人 簽 章：

中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

(限力晶積成電子製造股份有限公司申請股票初次上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：第一金證券股份有限公司

評 估 人 簽 章：彭　思　綺

單位主管簽章：羅　森　和

負 責 人 簽 章：陳　致　全

中　華　民　國　110　年　7　月　29　日

(限力晶積成電子製造股份有限公司申請股票初次上市證券承銷商評估報告使用)

協辦證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

評 估 人 簽 章 ：陳錦美

單位主管簽章：張嘉紋

負 責 人 簽 章 ：王濬智

中 華 民 國 110 年 7 月 29 日

(限力晶積成電子製造股份有限公司申請股票初次上市證券承銷商評估報告使用)

【附件十九】

股票上市前現金增資發行新股之證券承銷商評估報告

力晶積成電子製造股份有限公司

一一〇年度現金增資發行新股
證券承銷商評估報告

元大證券股份有限公司

中 華 民 國 一 一 〇 年 10 月 19 日

目　錄

壹、承銷商總結意見.....1
貳、評估報告內容摘要.....2
一、產業概況.....2
二、發行人之競爭地位.....7
三、營運風險.....7
四、最近期及最近三個會計年度募集與發行有價證券籌資效益.....118
參、就發行人下列業務財務狀況蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....119
一、業務狀況.....119
二、財務狀況.....179
肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....206
一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫.....206
二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益.....206
三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響..207
四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務周轉困難情事.....207
五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開.....210
伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論 211
一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質依附表九之一中所列事項詳與評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行.....211
二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事.....211
三、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定.....219
四、法令之遵循及對公司營運影響.....229
五、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師未具有下列情事.....234
陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....235
一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性.....235

二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估.....237
三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性.....237
三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性.....238
四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應評估其可行性與合理性.....238
五、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響.....238
六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，應評估事項.....238
七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性.....239
柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....239
捌、就本次公司債發行（及轉換）辦法之下列各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....239
玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....239
拾、就本次發行公司債債權確保情形（列明有無擔保、擔保品種類與價值等）蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果.....240
拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....240
拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....240
拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....240

壹、承銷商總結意見

力晶積成電子製造股份有限公司(以下簡稱力積電或該公司)本次為辦理初次上市現金增資發行普通股130,000千股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總額為新台幣1,300,000千元整，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，力積電本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

承銷部門主管：林佩宸

中　華　民　國　一　一　〇　年　10　月　19　日

貳、評估報告內容摘要

本承銷商經依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券評估報告之評估查核程序」規定辦理查核完畢，所獲致結論如下：

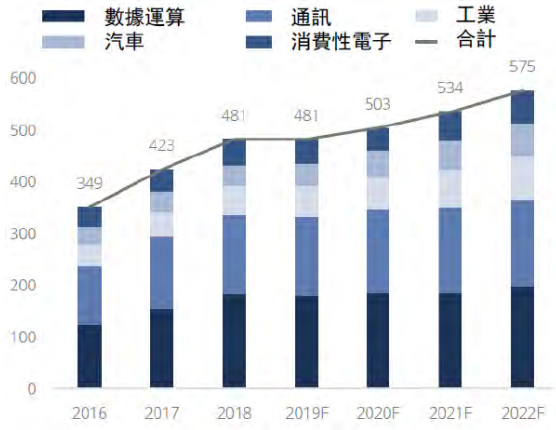
一、產業概況

該公司及其子公司主係從事半導體晶圓代工服務，主要產品分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，為各種電子產品中不可或缺的關鍵原料。邏輯暨特殊應用產品晶圓代工產品包含高壓製程產品、分離式元件產品、CMOS 影像感測器產品、電源管理晶片產品及嵌入式非揮發記憶體產品等；記憶體產品晶圓代工產品包含動態隨機存取記憶體產品及快閃記憶體產品(NAND/NOR Flash)。該公司及其子公司所生產之產品主係應用於電腦產品(Computer)、通訊應用(Communication)、消費性電子(Consumer)及車用電子(Automotive)等電子終端產品，茲就該公司及其子公司產品概況說明為：

(一)全球半導體產業概況

半導體技術的發展可追溯到一百年以前，從 1960 年代開始將電晶體、電阻及電容放在一個小矽晶片上構成大而複雜的電路，甚至整個系統(如計算機、收音機、電視機)，堪稱半導體積體電路(Integrated circuit：IC)之先驅，並帶動了科技呈現跳躍式的發展。IC 晶片為所有設備或裝置的基礎，藉由編輯應用程式控制設備或裝置，不斷改變人類的生活。複雜的半導體晶片可以協助智慧型手機、汽車、使用網路、雲端數據、工業自動化、智能家庭和消費性電子產品的技術發展，反過來說，隨著對關鍵技術發展要求及需求的成長，對半導體的需求也呈現成長趨勢。

主要科技應用程式潛在市場(單位:10 億美元)



資料來源：星展銀行整理

在 108~109 年各國開始全力支援 5G 商轉，領先推出的國家有南韓、美國、澳洲、英國及中國大陸等國，宣告全球正式邁入 5G 世代，110 年將有更多品牌廠商推出多款 5G 手機。5G 技術以高速傳輸、低延遲及大量連網為特色，除了 5G 基礎建設帶動的商機，也將引發終端設備新一波的升級換機需求。

另隨著運算能力增加及資料傳輸速度的提昇、各種網路及雲端數據蒐集技術逐步成熟的情況下，利用數據發展人工智慧(Artificial Intelligence，AI)成為近年相當重要的科技議題，預估 AI 在終端裝置上的應用，將朝向以下六大方向進行：語音助理、進階攝影、直覺化使用介面、降低功耗以延長電池使用時間、增進連線品質與增加個人安全性防護等。AI 也逐步往全方位的終端應用發展，包括智慧型手機、智慧穿戴、無人機、智慧家居、智慧工廠、智慧駕駛輔助，智慧行動醫療、公共／安防管理或是基因序列等終端應用都將接軌 AI。待 5G 商轉有成及 AI 時代來臨，串連起物聯網、車聯網、智能環境、人像或語音辨識等應用場景及行為習慣，將帶來半導體產業一連串的變化與商機。

同時因 AI 技術及效能的提升，物聯網及 5G 行動通訊建設臻於完善，興起許多新型態終端產品，使晶片設計複雜度不斷提昇；除追求晶片功能整合及低功耗外，還需考慮生產效能或是進一步要求半導體製程技術微縮。12 吋晶圓廠已經是半導體的主流供應尺寸，產業新競爭者的進入門檻較過去要更高。加上近幾年，全球 IDM 大廠朝向 Fab-lite 轉型趨勢漸趨明顯，逐步擴大晶圓委外代工訂單，臺灣晶圓代工產業成為這波轉型潮最大受惠者。該公司及其子公司擁有充裕的 12 吋先進製程晶圓產能並專注於利基型的製程，已陸續吸引許多國際 IDM 廠及無晶圓(Fabless)設計公司成為該公司及其子公司的代工客戶。

有鑑於 AI 及 5G 產業的逐漸成熟，未來終端產品對於高速及低功耗的客製化產品需求更甚，該公司及其子公司針對此市場趨勢，積極開發更符合客戶需求的特殊邏輯製程及記憶體產品製程，以提供客戶更具市場競爭力的晶圓代工服務。

回顧 109 年，年初因受新冠肺炎疫情肆虐及多國實施封城措施，使各國經濟成長受到影響，失業率攀升，但全球半導體產業卻因新冠肺炎疫情而受惠。新冠肺炎疫情迫使人們行為從「實體轉向虛擬」而帶動宅經濟，各類「宅經濟」相關晶片需求相對穩健，如電視機上盒(STB)晶片、遊戲用 PC、家用遊戲機熱銷、支援遠距教學及遠端辦公的伺服器晶片、安防監控相關晶片等。隨著各式電子產品需求逐漸回溫，又因恐新冠肺炎疫情再次升溫而斷料的恐慌心理，使各供應鏈提前備料更加積極，導致上游晶圓代工廠產能吃緊，產能供不應求。展望 110 年，5G、AI、遠距需求及電動車仍為帶動產業成長的主要動能，將帶動晶圓代工、IC 設計、Wi-Fi 6、矽晶圓、設備材料、車用電子、動態隨機存取記憶體(DRAM)、被動元件、5G 設備等需求旺。110 年半導體產業將延續 109 年的供需吃緊狀況。

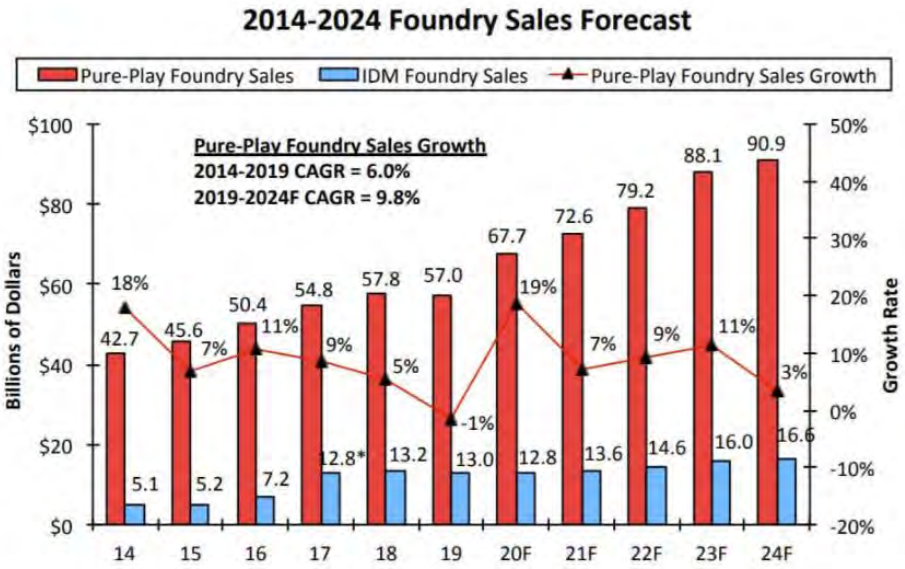
(二)晶圓代工產業概況

1.晶圓代工產業整體概況

半導體之製程技術及產品良率與生產成本關係密切，故各廠商為達到規模經濟之生產，莫不致力於產品良率與製程技術之提昇。根據摩爾定律，每隔兩年晶片內之電晶體數目就會成長一倍，在近幾年製程進步速度加快下，其兩年之時間已縮短到一年半，因此本產業不但具有高度之技術水準，且技術變化速度亦相當快。

全球晶圓代工的模式興起於 1980 年代，由台灣積體電路製造股份有限公司開啟了專業晶圓代工之時代。邏輯晶圓主要用於智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子與消費性電子產品。

若以晶圓尺寸來區分，主要分為 8 吋及 12 吋，一般認為 12 吋晶圓優於 8 吋晶圓，係因更大的晶圓尺寸可以減少浪費，而且還可以提高晶圓代工廠的日產量。然而，8 吋晶圓的生產線非常成熟，部分晶圓代工廠設備已攤提完折舊，價格較具競爭優勢，生產主力為功率元件、電源管理 IC、影像感測器、指紋辨識晶片和顯示驅動 IC 等產品。根據 IC Insights 研究，在 5G 智慧型手機對應用處理器需求增加的推動下，純晶圓代工廠預計在 2020 年占晶圓代工廠總銷售額的 84.1%，從 2019 年到 2024 年，純晶圓代工廠的銷售預計達到複合年增長率 9.8%。

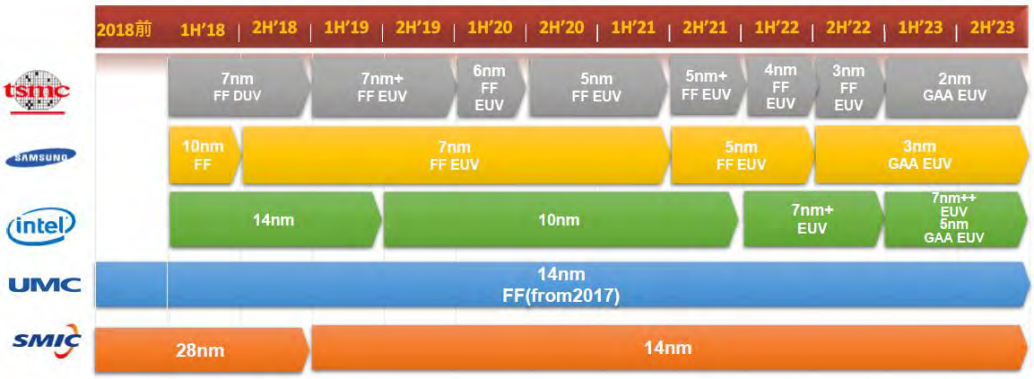


資料來源：IC Insights，SemiMedia(2020/09)整理

2.晶圓代工製程技術

107 年 8 月底全球第二大晶圓代工廠 GlobalFoundries Inc.(GF)宣布退出 7 奈米及以下先進製程的研發與投資，這是繼聯華電子股份有限公司後第二家宣布放棄 10 奈米以下製程的半導體公司。摩爾定律在 28 奈米節點之後，提升幅度減緩顯示先進邏輯製程不是市場唯一方向，放棄燒錢無止境的先進製程，轉向更有利潤的特殊應用產品市場，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊應用製程(應用於顯示驅動 IC、電源管理晶片、分離式元件、CMOS 影像感測器、嵌入式非揮發記憶體之製造)及多元代工合作模式，以有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是該公司及其子公司的競爭策略，28 奈米以上成熟製程市場依然有相當大的規模，包括 IoT、工業、汽車電子等應用。

製程演變

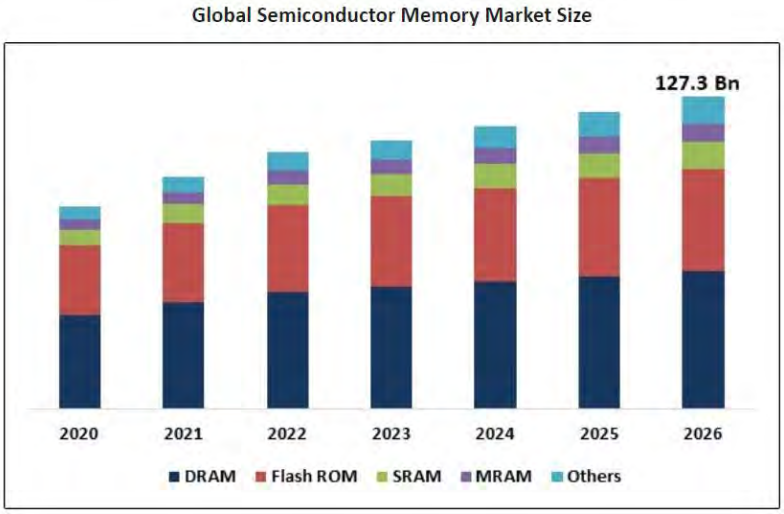


資料來源：工業技術研究院(2020/10)

(三)記憶體產業概況

1.記憶體產業整體概況

記憶體晶圓之製成品，依產品別可分為「記憶體模組」(DRAM Module)及「快閃記憶卡」(Memory Card)兩大類，前者主要應用於筆記型電腦(Notebook, NB)、桌上型電腦(DT)、伺服器(Server)及工業電腦(Industrial Personal Computer, IPC)等產品，後者則多應用於如數位相機、智慧型手機、電子遊戲機、平板電腦及攝/錄影機等可攜式電子產品。



資料來源：KBV Research(2020/07)

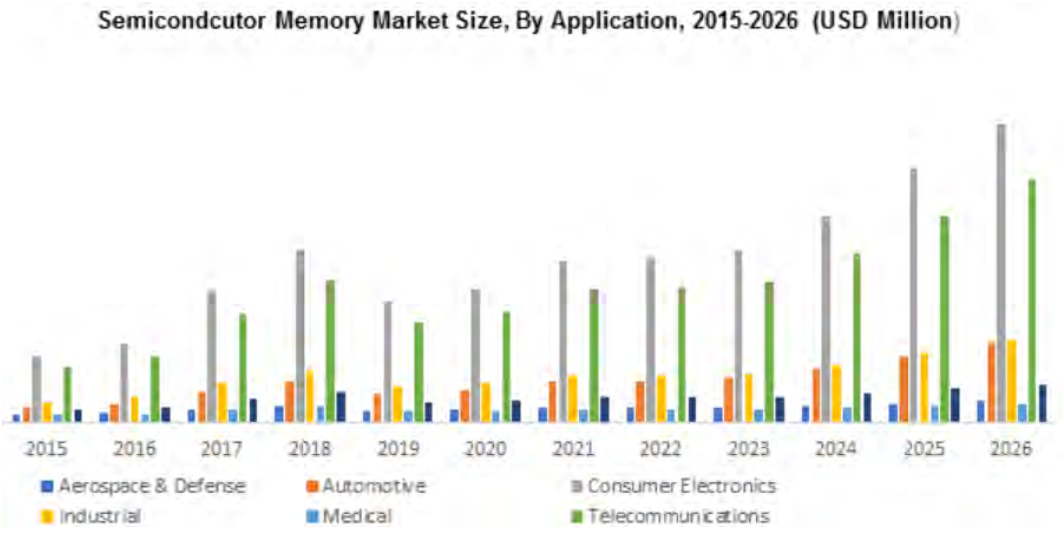
近年來，由於各大智慧型手機品牌商開始提高旗下手機 DRAM 的搭載率，以及美國、中國等主要國家加快大型資料中心的建置進程，而且為因應人工智慧(AI)、大數據(Big Data)、邊緣運算(Edge Computing)及伺服器(Server)等進階運用，因而對於 DRAM 及 NAND 型快閃記憶體(NAND Flash)有較顯著之需求。

107 年開始受到美中貿易戰、智慧型手機、伺服器等主要消費終端市場需求較為疲弱等因素影響，使得 DRAM 和 NAND Flash 價格皆出現大幅走跌，其中在 NAND Flash 方面，製程良率提高所造成的供給持續增加，加上買家縮手但供應商卻有較多庫存想賣，皆促使 NAND Flash 市場在 108 年第一季以前處於更明顯之供

給過剩狀態，使得下游應用產品外銷力道明顯減弱。然而，自 108 年第二季以來，NAND Flash 現貨價受惠於庫存去化已至尾聲、日韓貿易爭端刺激下游廠商提前備貨，以及東芝跳電停產減少供給而開始反彈，另外 DRAM 價格亦於 108 年 6 月出現落底跡象。

109 年開始，由於新冠肺炎疫情所衍生之電子競技、遠距工作及線上教學需求有效帶動伺服器及 NB 等相關記憶體的銷售，居家辦公及網路授課者對於消費型快閃記憶卡也具較顯著之需求。

記憶體晶圓未來成長動能為 5G 手機記憶體容量增加、高效能運算(Server/HPC)需求持續成長及車用/IoT 產品運算效能提升需求。根據 Global Market Insights 研究，記憶體半導體應用以消費性電子產品為大宗，其次是通訊產品。



資料來源：Global Market Insights(2020/02)

2.動態隨機存取記憶體製程技術

由於終端電子產品需求朝向性能提升、輕薄化及節能等趨勢下，晶片設計更需高度功能整合，其在高效能與低功耗等需求更需較高階製程記憶體產品支持。目前利基型動態隨機存取記憶體代工已導入 25 奈米製程，同時更加速 25 奈米以下新製程平台開發。另有因應人工智慧之類神經網路計算系統所需 AI Memory(記憶體式運算, In-Memory Computing；IMC)，並開發能與邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體，以滿足客戶不同的客製化記憶體需求，這些都能突顯該公司及其子公司提供記憶體產品代工之產業的地位。該公司及其子公司正與客戶或其他主要供應商密切合作，以切入成長強勁的人工智慧領域需求的半導體市場。

3.快閃記憶體(NAND/NOR Flash)製程技術

該公司及其子公司瞄準行動應用裝置、消費性電子產品及工業應用市場，提供低功率節能及高可靠度的 Flash 產品。低容量 NAND Flash 搭配 low-power DRAM 成為入門無線通訊產品主要的記憶體方案。此外，低容量 NAND Flash 也普遍運用於消費性電子產品、通訊產品及汽車聯網或工業應用。目前 28 奈米 NAND Flash 製程已成功進入量產階段。

近年來，許多新興的應用創造更多的 NOR Flash 記憶體需求，如無線藍牙耳機(TWS)、有源矩陣有機發光二極體面板(AMOLED 面板)或是 5G 基站設施都有 NOR Flash 需求。因應這些新興應用產品需求，帶動全球 NOR Flash 市場觸底反彈，回到全球年營業額 20 億美金以上。該公司及其子公司積極開發新一代 48 奈米 NOR Flash 製程，已於 110 年第二季量產；將能提供客戶更高容量、更有成本競爭力並能兼顧品質可靠度要求的 Flash 產品。

二、發行人之競爭地位

該公司及其子公司主係從事半導體晶圓代工服務，主要產品分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，根據國際研究機構 Omdia 針對 109 年全球晶圓代工總產值預估達 664 億美元；統計該公司及其子公司 109 年全年合併營收為新臺幣 456.8 億元，在全球晶圓代工市占率約達 2.3%，排名第六大。然該公司及其子公司在資源整合效益下，未來市占率可望有所提升。

三、營運風險

(一)行業營運風險

1.景氣循環之營運風險

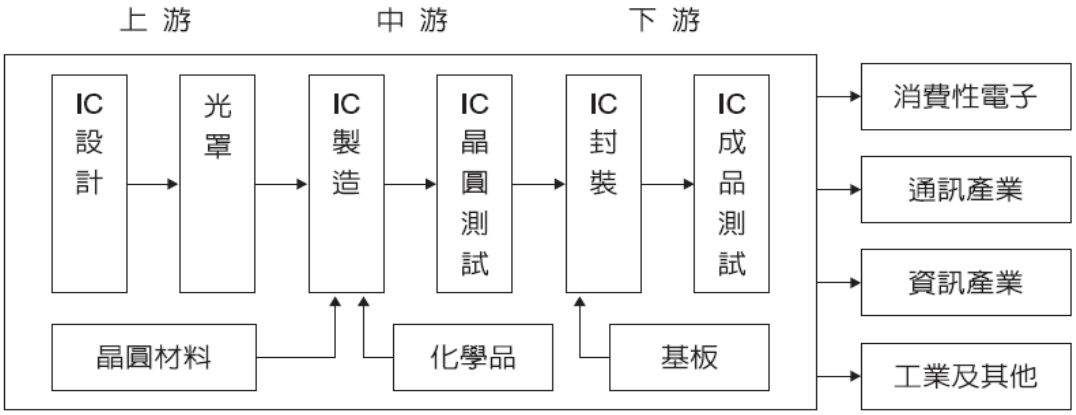
該公司及其子公司憑藉研發團隊多年研發設計經驗，以及與客戶多年合作關係，能夠快速提供符合客戶需求之客製化產品，各製程需要昂貴的設備、專利及良率關鍵 Know-how，進入門檻較高，產品應用面廣泛，因此該產業較無產品生命週期短促或產品世代交替快速之風險。

該公司及其子公司目前以生產記憶體晶圓、邏輯晶圓為主，生產排程配合市場價格及終端市場需求轉換產能，當單一終端產業受到季節性因素衝擊時，因記憶體晶圓、邏輯晶圓應用層面廣泛因而可分散風險，較不易受到景氣循環之波動而產生顯著負面影響。

在新冠肺炎疫情之下，各國紛紛實施封城計畫、居家辦公及遠距教學之下，帶動資料中心、筆電、平板電腦、固態硬碟及網通設備等產品的出貨量，同步刺激相關晶圓代工。又由於人們不敢搭乘大眾交通工具，在防疫規範逐步放寬後，汽車的需求量直線攀升，進而引發車用晶片短缺危機。近年來 5G、人工智慧物聯網(AIoT)等快速興起，也需要大量的晶圓。綜上所述，顯現目前半導體產能不足，該行業尚處於成長之利基市場，並無明顯景氣循環之營運風險。

2.行業上中下游變化之營運風險

半導體產業，泛指所有 IC 設計、生產製造及封裝測試半導體元件相關產品的產業。依功能可將積體電路分為四類產品：記憶體 IC、微元件、邏輯 IC 及類比 IC。IC 設計的種類很多，且具有不同特性，對於製程上的要求也不同，故晶圓製造廠及產業鏈間也須與客戶設計及製程需求與時俱進，以符合終端產品規格，並帶動整體產業鏈發展；故半導體產業之上、中、下游之關聯性為：



資料來源：工研院經貿中心 ITIS 計畫、該公司及其子公司提供，元大證券整理

3.行業未來發展之營運風險

(1)高效能、高頻寬、低功耗

隨各項電子終端產品，如電腦產品(Computer)、通訊應用(Communication)、消費性電子(Consumer)及車用電子(Automotive)產品等生產技術漸趨成熟，智慧型手機產品的普遍級人工智慧相關產品的推出，促使物聯網(IoT)產業鏈逐漸成形，更帶動上下游相關元件需求。終端產品要求「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，對晶圓代工廠而言，提供客戶客製化製程開發晶圓之體積小、低耗電量及多功能更顯重要，邏輯晶圓與 DRAM 晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的 AI 晶片，兼具高效能、高頻寬及低功耗優勢的新世代半導體製造技術突破，預料將為晶圓代工產業開創新局。

(2)新應用市場需求旺盛

車用、5G 及人工智慧物聯網(AIoT)等晶片快速興起，已對全球半導體產業造成結構性的改變，目前市場對成熟製程的晶片需求出現大爆發的情況，未來供不應求將更嚴重。許多國家近期皆洽詢其他國家半導體製造商，希望取得晶圓產品的供應，以德國為例，經濟部長洽詢臺灣半導體製造業者，渴望半導體製造商製造排程順序能夠調整，以為該國車用廠商優先取得車用晶圓，緩解其製程瓶頸。新的智能終端產品層出不窮，使晶圓市場前景越來越廣闊，未來晶圓供不應求的趨勢將會更加顯著。

(3)中國政府強力扶植中國半導體製造業

中國政府祭出多項扶植政策來強化半導體鏈國產化的發展速度，如積極採取政策、資本、創新等三方的扶植政策，例如：(一)二期積體電路大基金：除了布局投資製造類、擴大對設備及材料領域的投資，亦會布局 5G、AI 相關設計領域，顯然投資範圍較一期積體電路大基金為大。(二)新時期促進積體電路產業與軟體產業高品質發展若干政策：主要以稅賦的減免為主。(三)將第三代半導體列入十四五計畫、中共中央關於制訂國民經濟及社會發展第十四五年規劃和 2035 年願景目標的建設：尚未對實際的作法有更深入的方針。

(4)美國奪回半導體產業主導權

在新冠肺炎疫情及美中貿易戰之下,為鞏固美國在未來新興科技領域的全球領導地位，美國體認到自主控制供應鏈的重要性，因而實施：(一)加強投資美國國內半導體產業：美國半導體產業協會(SIA)建議美國政府投入 370 億美元籌組美國國家隊。(二)拉攏外國半導體製造業至美國設廠：台積電於 2020 年 5 月 15 日宣布將在美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠，將採用 5 奈米製程，預計 2021 年動工、2024 年量產，投資金額約 120 億美元。(三)切斷華為供應鏈，影響相關半導體產業：美國修改出口管理條例，要求全球所有公司只要利用到美國的設備和技術幫華為生產產品，都必須經過美國政府批准，另一方面，中國方面也開始反擊，對重量級美國企業展開報復(施以反壟斷或網路安全調查)，要求中國科技供應鏈加速去美國化。

4.產品可替代性之營運風險

晶圓運用之範圍相當廣泛，各項電子終端產品，如電腦產品、通訊應用、消費性電子、車用電子產品及物聯網(IoT)相關產品等皆必須使用晶圓，因此下游終端產業的成長，將帶動對晶圓的需求成長。在 5G 及高效能運算(HPC)需求帶動下，市場出現結構性變化，加上全球經濟改變，現代人們工作及生活型態都不同以往，推升晶圓成為不可或缺的產品，尚無其他產品可替代。

(二)發行公司營運風險

1.業務之營運風險

(1)市場未來供需變化情形

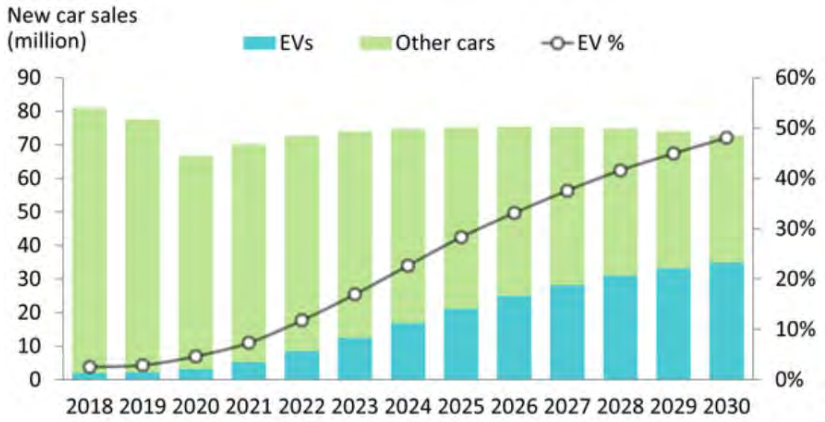
根據 WSTS(全球半導體貿易統計協會)統計 109 年全球半導體，市場產值達 4,330 億美元，較 108 年的 4,123 億美元增長 5.1%，較先因前受新型冠狀病毒(COVID-19)影響下修至 3.3%的成長預期為優。WSTS 預計 110 年全球半導體市場增長將加速，110 年全球半導體產值可望年增約 8.4%，主要成長動能來自於 Sensor、Logic 及 Memory 等相關產品；研調機構顧能 Gartner 也預期 110 年半導體市場將成長 11.6%以上水準。近年由於 IDM 大廠在樽節資本支出及降低成本考量下，增加委外代工比重，有助於晶圓代工廠營收表現。根據國際研究機構 Omdia 預估 110 年純晶圓代工產值預期有 15.4%的正成長，表現相對優於整體半導體產業。

自新冠肺炎疫情爆發以來，迄今已擴散全球，目前尚未能有效控制，加上中美貿易戰日益加劇,引發市場多種不確定性,或對於產品終端需求造成遞延效應,需更密切觀察其後續對全球經濟造成的影響。

車用(電動車、Smart Car 自動駕駛)、5G、AloT (小型處理器)等晶片新需求快速興起，已造成全球半導體產業結構性的改變，目前市場對成熟製程的品片需求出現大爆發，而且未來供不應求將更嚴重。

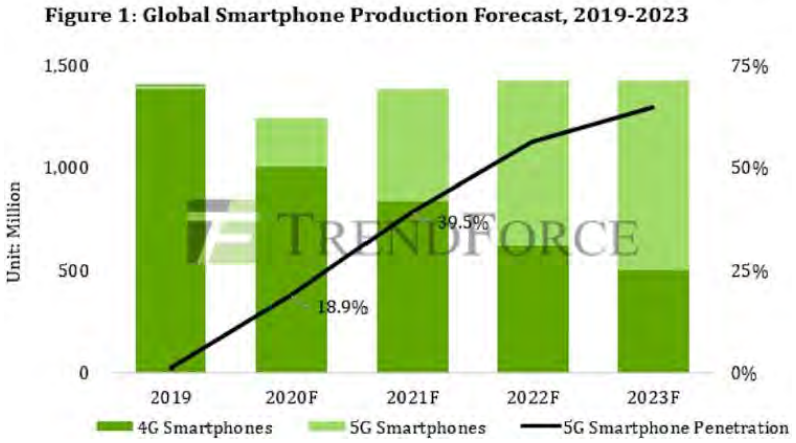
汽車工業已經從單純機械組裝製造發展到安裝電子零組件藉以提升性能、效率、安全性和舒適性。目前的汽車創新主要是電子功能創新，並逐步往自動駕駛邁進。109 年電動汽車占所有新車銷售約 5%，預計 110 年電動汽車將占全球新車銷售的 7%以上，銷量將超過 500 萬輛；預計到 119 年，電動汽車將占全球乘用車總銷量的近一半。

2018 年~2030 年汽車變化情形



資料來源：Canalys estimates(2021/01)

隨著智能手機從 4G 往 5G 邁進，雖 5G 網絡基礎建設的進度尚未普及，但各家智慧型手機品牌和移動處理器製造商為搶得商機，皆努力擴大在 5G 市場的份額，根據 TrendForce 研究報告，109 年 5G 智慧型手機已達 18.9%，110 年將成長至 39.5%，預計 111 年將達智慧型手機半數。



資料來源：TrendForce(2020/07)

(2)影響該公司及其子公司未來發展之有利及不利因素及其相關因應措施

A.有利因素

(A)市場需求穩定成長

物聯網及人工智慧的發展，創造許多由 Cloud 端到 Edge 端不同且多樣的半導體需求。在全球智慧手機發展成熟之際，提供了另外一項半導體市場長期的成長動能。於邏輯產品之技術方面，該公司及其子公司充份發

揮 12 吋 80nm 以上鋁製程成本優勢，在 DDIC/PWM/MCU/CIS 等特殊代工產品領域與客戶深度合作，並進一步延伸至 55nm 以下銅製程。於 8 吋則重心由 IC 擴大至分立器件，以 MOSFET/IGBT/GaN 等產品線為未來主要成長動能。8 吋及 12 吋未來目標是都要能兼顧穩定獲利及持續成長。另，於記憶體產品之技術方面，該公司及其子公司除擁有完整的記憶體設計服務及製造能力外，且同時具備 DRAM 及 NAND/NOR Flash 製程平台，能夠滿足客戶多元化的記憶體產品需求。該公司及其子公司將持續開發新一代記憶體製程，維持成本競爭優勢，並與代工客戶共同合作提供多樣化、高品質的記憶體產品。

(B)產品多元

該公司及其子公司兼容邏輯製程及記憶體製程代工產能配置，有利於公司於景氣波動循環中進行產能彈性調配，提高產能利用率，使該公司及其子公司能維持相對於代工同業較佳的穩定獲利。

(C)高客製化程度

該公司及其子公司以先進技術提供 8 吋及 12 吋晶圓專業代工服務。不僅提供利基型記憶體先進製程以協助國內外客戶生產相關產品，為目前全球主要提供全方位記憶體產品線代工之 12 吋晶圓廠。同時，提供客製化的邏輯暨特殊應用產品代工服務，成為世界級大廠的最佳合作夥伴。

B.不利因素

(A)同業競爭壓力增加

近年半導體產業主要支撐力道來自於行動裝置、5G、AI 等產品，各相關邏輯元件晶圓代工廠亦受惠，引起業界關注。而近年中國政府致力於半導體產業扶植，以打造產業鏈一條龍為目標，積極投入設備及廣納人才。在全球代工產能供給增加的情況下，可能會面臨與同業競爭壓力。

<u>因應對策</u>

該公司及其子公司以世界級同步的技術，搭配國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的代工服務，以共創事業高峰。至今已陸續引進不同的代工客戶，客戶的產品可應用的範圍涵蓋了 3C 應用領域－電腦、無線通訊、消費性電子及車用電子等。

同時藉由擴大與全球產官學研究機構共同進行相關製程技術開發，以期提早掌握前瞻技術，有效縮短研發時程，降低專利與技術移轉成本。該公司及其子公司持續提供更優質的服務、產品及多元代工模式，以持續深化與客戶良好關係，為該公司及其子公司最佳的因應之道。該公司及其子公司的 12 吋廠與 8 吋廠整合後，係可提供客戶更完整的產品線及更完善的服務品質。

(B)產能擴充之可能風險

因 12 吋代工客戶產能需求持續攀升，該公司及其子公司 12 吋產能已常態性無法滿足客戶需求。為滿足中長期營運規劃，該公司及其子公司在充分評估後，已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構該公司及其子公司最新 10 萬片 12 吋生產基地。惟因需求預測會隨著市場環境變化而產生顯著的改變，當需求減少時，已添購的機器設備及增聘的人員等將造成對該公司及其子公司財務表現產生負面的影響。

因應對策

該公司及其子公司會持續觀察市場變化並與客戶緊密合作，若市場需求不如預期時，該公司及其子公司會及時調整其產能計劃，以降低對於公司財務表現的負面影響，且該公司及其子公司相關投資計畫尚在規劃中，原則以分期、分階段，以公司財務可負擔，最小風險下擴充廠房及產能，同時兼顧公司穩健成長與滿足客戶產能需求。

該公司及其子公司亦將擴廠設備風險轉嫁給客戶共同承擔，對上游 IC 設計業者來說，即使本身公司設計具有競爭力，但沒有配合製造的產能也無濟於事，因此未來五年，邏輯晶圓代工產能將成為兵家必爭之地，而客戶端爭搶產能動作更加積極。目前該公司及其子公司與部分客戶間採取 Consign 的模式，由客戶購買機器設備租予該公司及其子公司，再由該公司及其子公司代工產出產品，客戶可確保後續晶圓取得無虞，該公司及其子公司也能降低購買大量設備後需求減緩的風險。

(C)有關智慧財產權之風險

該公司及其子公司係以自行研發的製程技術、營業秘密及相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，然而尚無法保證營業秘密及相關 know-how 不被竊取或仿效，若發生此情事，將導致該公司及其子公司營收減少之可能性，也有可能在不知情的情況下侵害到他公司的智慧財產權，若有相關訴訟可能導致該公司及其子公司有無法製造特定產品的風險。

因應對策

該公司及其子公司已採取相關措施以儘量減少因智慧財產權的主張與訴訟而導致股東權益損失的可能性。包含積極主張及保護該公司及其子公司所屬之智慧財產權，對於研發成功之產品基於智慧財產權，皆有申請專利保護。該公司及其子公司設有智權室防止製程中有侵害他人智慧財產權之情事，另外對於使用到的專利，皆有取得其他公司的授權，避免有侵權的風險。

(D)氣候災害風險

半導體製造業對電力的供電量及穩定度皆有強大的要求，若發生偶發性斷電將需要重啟設備及檢查機台，因而影響產品製程進度。半導體製造

業對營業用水需求量大，若有缺水的情況也將影響產能。任何氣候災害造成缺水缺電皆有影響產能的風險。

因應對策

該公司及其子公司設有不斷電系統，避免有斷電的情況，對於水資源致力回收使用，減少對水資源的損耗，並對無法於廠內再次使用之廢溶劑落實機台分流設計，於排放管路裝上選別閥進行切換排放管路，有效減少廢溶劑之排放量，且將其餘廢水排入廢水場或回收系統，進行水回收使用，使得該公司及其子公司 109 年度 8A 廠製程用水回收率達 85%以上。

該公司及其子公司與政府部門有良好的溝通渠道，氣候災害風險管控皆有充分討論因應對策，並已密切監控水情狀況，於水情吃緊時備妥水車，一旦有需要便可啟動至與政府協商的地區載水應急。

(E)匯率風險

該公司及其子公司營收不論內外銷，皆採外幣計價，交易幣別採美元交易，惟該公司及其子公司資本支出及進貨付款幣別主要有美元、日幣及新臺幣，無法互抵之美元應收款項在轉換成新臺幣時，仍會因持有美元淨資產部位而產生匯兌損益。故在美元持續貶值趨勢之情況下，兌換損失可能將侵蝕公司之獲利。

因應對策

該公司及其子公司因應匯率變動之管理以避險為目的，不以獲利為目的，採自然避險及配合遠期外匯合約以規避匯率風險；另財務單位密切留意國際金融狀況，掌握最新之匯率市場變動，並請往來銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率走勢，並視實際外幣部位和資金狀況，於政策許可之範圍內，配合遠期外匯合約以規避匯率風險。

(3)公司競爭利基

A.專業研發團隊

研發人才與製程技術具有密切的關係，若僅具有先進之設備與製程參數，無優秀之研發人才則不易發揮良好的生產效率。該公司及其子公司深知優秀人才為公司永續經營之重要因素，故藉由配股及分紅制度吸引優秀研發人才，該公司及其子公司之研發團隊碩博士以上學歷員工占研發人員比率半數以上，最近期為 68.22%，且大多已具備相關產業研發工作資歷。

該公司及其子公司之技術研發主係專研各種邏輯與記憶體代工製程技術平台，為客戶提供一流之代工服務，以期在邏輯代工與記憶體代工製程技術上與世界一流廠商並駕齊驅。截至目前為止，該公司及子公司已取得 943 項專利權且尚有 335 項申請中專利權。

B.價格競爭優勢

該公司及其子公司 8 吋及 12 吋廠製程良率優異，與世界大廠同步，在先進製程上具備成本競爭力優勢，並與策略聯盟夥伴合作建立共同的設計平台和 IP，提供客製化的晶圓代工服務，包括邏輯暨特殊應用產品、利基型動態隨機存取記憶體及 NOR/NAND 快閃記憶體等領域的晶片專業代工服務，並積極導入國際大廠與之合作，開發多樣產品。以世界級同步的製造技術及國際級的製造水準及嚴格品管，提供客戶滿意的優異代工服務。

而有別於一般市面上 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，該公司及其子公司能提供低成本的 12 吋鋁製程平台，相較同樣技術節點的 8 吋鋁製程，該公司及其子公司 12 吋鋁製程晶粒成本可大幅降低 30%以上，大幅提昇客戶產品競爭力。

C.邏輯晶圓與 DRAM 晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的 AI 晶片

考量到終端電子產品需求朝向性能提升、輕薄化及節能等趨勢下，晶片設計更需高度功能整合，其在高效能與低功耗等需求更需較高階製程記憶體產品支持。目前利基型動態隨機存取記憶體代工已導入 25 奈米製程，同時更加速 25 奈米以下新製程平台開發。另有因應人工智慧之類神經網路計算系統所需 AI Memory(記憶體式運算, In-Memory Computing；IMC)，並開發能與邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體，以滿足客戶不同的客製化記憶體需求，這些都能突顯該公司及其子公司提供記憶體產品代工之產業的地位。該公司及其子公司正與客戶或其他主要供應商密切合作，以切入成長強勁的人工智慧領域需求的半導體市場。

2.技術能力、研發及專利權之營運風險

(1)取得技術專家之評估意見佐證

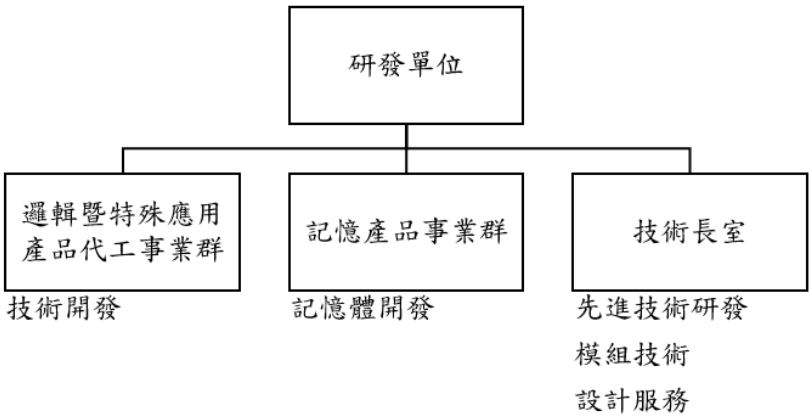
本證券承銷商與該公司並未委請技術專家就該公司及其子公司之研發技術能力出具意見或報告，故不適用本評估事項。

(2)取得發行公司研究發展部門之沿革、組織、人員、學經歷、研究成果及未來計畫等資料，以了解主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額，暨研發工作未來發展方向，並分析最近期及最近三個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、流動情形及離職率等資料，評估研發人員離職對發行公司之營運風險

A.研發部門之沿革及組織

該公司及其子公司為厚植技術競爭力，成立研發團隊，研發組織架構係採專業分工管理，研發主管其下轄單位為技術開發、記憶體開發、先進技術研發、模組技術及設計服務。茲將該公司及其子公司研發部組織圖及所轄各職掌分別列示如下：

(A)研發部門組織圖



資料來源：該公司及其子公司提供

(B)研發單位職掌

單位	工作內容
技術開發	開發邏輯及特殊運用產品之製程技術，以增加晶圓代工產能利用率，並將已開發之新製程移轉至 FAB 廠順利量產，累積技術開發能力。
記憶體開發	DRAM 與 FLASH 技術研發之規劃、評定、驗證及自有、代工產品之量產。
先進技術研發	執行平台技術、應用技術及特殊邏輯技術之開發計畫，並順利導入量產。
模組技術	模組製程技術開發與導入並負責量產前之維護，持續導入新製程及材料以符合客戶產品世代的演進。
設計服務	建立自有IP開發與分析的能力，並建立維護及管理，驗收內容與驗證機制。

資料來源：該公司及其子公司提供

B.最近期及最近三個會計年度研發部門人員之人數、平均年資、學經歷、流動情形及離職率

單位：人；年；%

年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
期初人數	742	1,129	1,107	1,162
新進人員	87	53	124	80
離職人員	69	60	70	64
資遣人員	—	6	3	1
退休人員	—	2	1	0
部門異動	369	(7)	5	(6)
期末研發人員合計	1,129	1,107	1,162	1,171
平均年資(年)	8.02	8.68	8.96	9.37

年度		107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
離職率(註)		5.76%	5.79%	5.99%	5.26%
學歷分佈	博士	33	37	42	43
	碩士	693	685	743	763
	大學(專)	384	366	357	345
	高中(職)及以下	19	19	20	20

資料來源：該公司及其子公司提供

註：離職率=(離職人數+資遣及退休人員)／(期末人數+離職人數+資遣及退休人員)。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至 9 月底研發人員分別為 1,129 人、1,107 人、1,162 人及 1,171 人，最近三年及最近期研發人員占公司員工總數分別為 16.29% 、16.09%、16.20%及 16.03%，顯示該公司及其子公司對研發相當重視，其中博士以上學歷員工分別為 33 人、37 人、42 人及 43 人，碩士以上學歷員工分別為 693 人、685 人、743 人及 763 人，碩博士占研發人員比率分別為 64.30%、65.22%、67.56%及 68.83%，占總研發人員半數以上，且大多已具備相關產業研發工作資歷，顯示該公司及其子公司對研發人員之素質相當重視。

在研發人員流動情形方面，107 年度部門異動 369 人為公司組織調整，將原屬於製造部門試產的人員，調整至研發部門； 107~109 年度及 110 年截至 9 月底離職率分別為 5.76%、5.79%、5.99%及 5.26%，除 108 年離職中有 3 人、109 年離職中有 1 人及 110 年截至第三季離職中有 3 人為主管級以外，其餘離職人員皆為非主管級，離職原因主要係為個人職涯規劃或家庭因素等，該等離職人員交接程序皆已辦妥，業務上之銜接亦無中斷情形，故尚不足以對該公司及其子公司研發計畫及進程造成顯著影響，而該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至 9 月底新進人數皆足以支應離職人數，研發組織人力配置尚維持穩定。

該公司及其子公司研發人員在職期間之相關研發成果皆屬該公司所擁有，且對於所有研發人員均簽訂工作契約，其內容主要規範機密資訊之保密義務，為避免人員流動造成研發中斷風險，該公司及其子公司對於研究計畫、研發過程及結果皆有完整之記錄保存且訂定相關研發循環內控管理之，對於研發成功之產品基於智慧財產權，亦申請專利保護，故人員異動對於該公司及其子公司並無技術傳承困難之情事。整體而言，研發人員之流動尚不致對該公司及其子公司研發部門之運作及公司整體營運產生重大之影響。

C.最近期及最近三個會計年度研發費用

單位：新臺幣仟元

項目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
研發費用	3,453,483	2,962,370	3,234,765	2,951,790
當年度營業收入淨額	49,913,779	35,897,121	45,684,615	45,865,144
占當年度營收淨額比率	6.92%	8.25%	7.08%	6.44%

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至 9 月底研發費用分別為 3,453,483 仟元、2,962,370 仟元、3,234,765 仟元及 2,951,790 仟元，占各年度營業收入淨額之比率分別為 6.92%、8.25%、7.08%及 6.44%，研發費用主要為研發人員薪資、獎金、設計修改及測試相關專業服務費、製程技術改善費、電腦使用費、相關設備之折舊、耗材費等支出。108 年度研發費用金額較 107 年度減少 491,113 仟元，主係因該公司及其子公司 108 年度因邏輯產品之需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，當年度營業收入較 107 年度下降，使獎金等帳列薪資費用減少且員工酬勞減少，故 108 年度研發費用占當年度營收淨額比率較高；109 年研發費用金額較 108 年度增加 272,395 仟元，主係因該公司及其子公司業績成長，調增研發人員薪資、發放獎金增加及員工酬勞增加所致；110 年第三季研究發展費用相較去年同期增加 573,547 仟元，主係因業績成長而薪資費用、員工酬勞估列數增加、製程及技術改善費以及折舊費用增加所致。綜上，該公司及其子公司最近三年度及最近期研發費用占年度營業收入淨額約 6.44%~8.25%，除 108 年度因營收減少，致研發費用占營收比重拉高，其餘期間之研發費用占各年度營收淨額比率約為 7%，顯示該公司及其子公司為維持於半導體業製造業的競爭力，致力於研發人員的培養投入以及生產技術的開發與產品研究。該公司及其子公司最近三年度及 110 年第三季研發費用之變動情形，尚無重大異常之情事。

D.重要研發成果

該公司及其子公司自成立以來，即不斷要求提升自身研發能力並致力於各項產品及製程技術之開發，該公司及其子公司除原有產品之效能及製程改良外，並持續投入新產品之開發，此外亦配合客戶之需求，由研發團隊與客戶共同設計研發產品，以原有製程再改善與產品再精進為目標。茲將該公司及其子公司最近三年度之重要研發成果及相關內容列示如下：

年度	內容說明	應用於
107 年度	55nm 1.2V/6V/32V	顯示驅動 IC
	180nm PMIC Porting in	電源管理 IC
	1200V IGBT Porting in	分離式元件
	0.15um DDI 1.8V/9V/18V	顯示驅動 IC
	0.11um eFlash & 0.11um EEPROM 6V	嵌入式非揮發性記憶體產品

年度	內容說明	應用於
108 年度	55nm DDI 1.2V/8V/20V	顯示驅動 IC
	40nm LOGIC 1.2V/2.5V	邏輯 IC 產品
	80nm DDI 1.2V/6V/32V	顯示驅動 IC
	0.15um DDI 3.3V/9V/18V	顯示驅動 IC
	Double Gate 30~40V	分離式元件
109 年度	55nm eFlash 1.2V/2.5V/5V	嵌入式非揮發性記憶體產品
	NOR48	快閃記憶體產品
	F38/F25 客製化 DRAM 與邏輯產品堆疊之技術驗證	1.邊緣運算、挖礦 2.high frame-rate CIS, Global Shutter
	0.65um UMOS	分離式元件

(3)說明主要技術來源、技術報酬金或權利金支付方式及金額

該公司及其子公司提供客戶自行研發之 IP，並與多家業界領先的矽智財服務、IP 供應商合作，向客戶提供從 0.35 微米到 55 奈米工藝平台經過矽驗證和優化的單元庫、IP，包括標準單元庫、IO 庫、記憶體模塊、編譯器、嵌入式非揮發記憶體 IP 等，滿足客戶對各種 IP 及晶片設計的需求。藉由配合客戶之需求，由研發團隊與客戶共同設計研發產品進行技術上之交流，必要時亦與大學或研究機構進行合作計畫，直接或間接提升公司技術能力，該公司及其子公司每年均持續投入研發資源，進行專案規劃及新產品開發，及長期累積豐富的實務經驗。依性質彙整如下表：

類別	合作對象	合約技術主要內容	技術報酬支付方式及金額
技術報酬金	財團法人工業技術研究院	製程開發	依合約
	學校	製程開發	依合約
	業界領先的矽智財服務及 IP 供應商	技術開發	依合約
權利金	業界領先的矽智財服務及 IP 供應商	製造一般晶圓之權利金	支付權利金方式如下： 1.依合約約定期間定額支付 2.依合約約定特定品項之出貨量乘以約定比例
		製造特定產品之權利金	支付權利金金額為依合約約定特定品項之出貨量乘以約定比例

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季權利金費用分別為 644,359 仟元、611,008 仟元、486,061 仟元及 496,376 仟元，分別占營業成本 1.86%、1.86%、1.40%及 1.78%。

(4)研發工作未來發展方向

該公司及其子公司主要產品為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，未來產品開發方向係沿用雙主軸晶圓代工能力的優勢，發展產品技術，

專注客製化產品，並發展獨步全球的與邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體製造技術；製程與技術開發方面，將朝提升製程技術能力，以提高生產效率及產品品質為工作發展方向。

產品別	未來發展方向
先進技術及模組開發	Interchip DRAM/Logic(WOW) 用成熟製程也能做 HPC(High Performance Computing)，大幅降低 HPC 成本，減緩先進製程產能壓力，成本與運算效能的優越性將使 3D InterChip 成為未來高性能、低功耗應用的主力。單位耗能所產生的運算能力(算力/耗電)超過 nVidia G4 1070(16nm 製程+GDDR5)9 倍，超過 AMD 旗艦型 GPU(7nm 製程+HBM2)6 倍。
邏輯產品代工技術開發	1. Logic/HV 從 55nm 開發推展到 40nm 和 28nm。 2. eNVM 延伸到 55nm 和 40nm。 3.CIS 則是量產推到 90nm，計劃開發 55nm。 4.Discrete 有車用半導體 IGBT、Super junction。IC 有 GaN、Panel source driver、PMIC、eFlash、OTP/MTP
記憶體產品代工技術開發	1.NOR Flash 由 90nm 進展到 48nm。 2.NAND Flash 由 40nm 推到 28nm、24nm。 3.DRAM 由 25nm 進展到 21nm、1Xnm。

(5)重要技術合作契約對申請公司及其子公司之營運風險

該公司及其子公司產品技術主要是依據客戶需求自行開發及改良，最近三年度及申請年度截至最近期止，除該公司及其子公司與愛普科技股份有限公司合作開發之邏輯晶片晶圓堆疊(WOW-Wafer On Wafer)的新型記憶體技術的 A.I.(Artificial Intelligence)人工智慧晶片、與國際通信大廠合作開發新一代 SiGe-HBT 技術及與比利時的 imec(愛美科，又稱比利時微電子研究中心)移轉氮化鎵功率元件技術外，並無有與他人共同開發技術之技術合作並簽訂重要技術合作契約之情事，其契約內容並未有重大不利之限制條款，故對該公司及其子公司營運尚無不利之影響。

(6)目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權之情形，有無涉及違反專利權、商標權及著作權等情事，暨因應措施是否合理有效

該公司及其子公司最近三個會計年度及截至目前為止，並無涉及違反專利權、商標權及著作權之情事，茲將該公司及其子公司已取得、申請中之專利權及商標權列示如下：

A.專利權

國別	發明		新式樣/設計		新型		合計	
	取得	申請中	取得	申請中	取得	申請中	取得	申請中
臺灣	419	162	—	—	2	—	421	162
美國	324	88	—	—	—	—	324	88
中國	168	146	—	—	2	—	170	146
日本	62	4	—	—	—	—	62	4
韓國	—	2	—	—	—	—	—	2
合計	973	402	—	—	4	—	977	402

資料來源：該公司及其子公司提供

(A)已取得

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
1	快閃記憶體的結構,製造方法及其操作方法	175995	2003/04/11-2022/04/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
2	記憶體元件之製造方法	176115	2003/04/11-2022/04/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
3	記憶體元件之結構及其製造方法	178281	2003/05/21-2022/05/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
4	快閃記憶體之製造方法	179649	2003/06/11-2022/06/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
5	快閃記憶體之製造方法	192348	2003/12/11 -2022/12/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
6	抑震裝置	I232200	2005/05/11-2023/12/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
7	半導體封裝結構及其製造方法	I233173	2005/05/21-2024/04/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
8	非揮發性記憶胞的製作方法	I233666	2005/06/01-2024/04/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
9	快閃記憶體的製造方法	I233665	2005/06/01-2024/02/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
10	非揮發性記憶體、非揮發性記憶體陣列及其製造方法	I233691	2005/06/01-2024/05/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
11	晶圓測試參數分析方法	I234217	2005/06/11-2022/12/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
12	彩色影像感測裝置及其製造方法	I234186	2005/06/11-2024/06/07	發明	臺灣	邏輯 IC
13	避免殘留氣體污染晶圓之設備及方法	I234801	2005/06/21-2024/05/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
14	具自動回復功能之晶圓測試裝	I235446	2005/07/01-2024/04/18	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	置與晶圓測試方法					生產製程
15	非揮發性記憶體及其製造方法	I235462	2005/07/01-2024/07/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
16	製程即時批次派工系統及其方法	I236044	2005/07/11-2024/05/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
17	管理半導體機台例行性維護之方法及相關系統	I235899	2005/07/11-2024/02/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
18	分析方法	I236080	2005/07/11-2024/08/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
19	P 型通道反及閘型快閃記憶體及其操作方法	I236141	2005/07/11-2024/11/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
20	驗證光罩的方法	I236081	2005/07/11-2024/09/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
21	製作阻障層之方法	I237327	2005/08/01-2023/11/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
22	漏氧檢測方法	I237339	2005/08/01-2023/12/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
23	利用單一蝕刻步驟形成矽尖角以及形成浮置閘極之方法	I237325	2005/08/01-2024/11/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
24	光二極體的製作方法	I237905	2005/08/11-2024/04/07	發明	臺灣	邏輯 IC
25	含氟廢水之處理方法	I238148	2005/08/21-2022/10/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
26	反及閘型快閃記憶胞列及其製造方法	I239077	2005/09/01-2023/10/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
27	快閃記憶體結構及其製作方法	I239600	2005/09/11-2023/11/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
28	半導體製程及良率分析整合即時管理方法	I239469	2005/09/11-2024/06/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
29	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I239641	2005/09/11-2024/04/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
30	廢氣排放處理系統	I239862	2005/09/21-2023/01/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
31	定位套件與定位方法	I239933	2005/09/21-2024/03/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
32	非揮發性記憶胞的製作方法	I240384	2005/09/21-2024/04/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
33	具有可變快門的曝光機台及其曝光方法	I240852	2005/10/01-2024/01/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
34	缺陷偵測及分類系統的資料分析方法	I240983	2005/10/01-2024/06/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
35	非揮發性記憶體元件及其製造方法與操作方法	I241017	2005/10/01-2025/01/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
36	溝渠式閘介電層的形成方法	I240989	2005/10/01-2025/01/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
37	非揮發記憶體的結構與製造方法	I243450	2005/11/11-2023/09/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
38	具有晶圓探針之測試系統及其顯微對準方法	I245903	2005/12/21-2022/04/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
39	多階記憶胞	I246187	2005/12/21-2023/10/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
40	活性碳過濾裝置之殺菌方法及水處理系統	I245745	2005/12/21-2023/12/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
41	快閃記憶胞及其製造方法	I246166	2005/12/21-2024/07/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
42	半導體機台之晶圓載台清潔治具	I246148	2005/12/21-2024/09/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
43	非揮發性記憶體的製造方法	I246749	2006/01/01-2025/03/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
44	非揮發性記憶體及其製造方法以及其操作方法	I246748	2006/01/01-2025/02/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
45	晶片缺陷資料庫建立方法	I247221	2006/01/11-2023/10/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
46	非揮發性記憶體之製造方法	I247391	2006/01/11-2024/09/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
47	半導體缺陷偵測方法與系統	I247376	2006/01/11-2024/12/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
48	廢氣排放處理設備	I247623	2006/01/21-2024/12/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
49	非揮發性記憶體的製造方法	I249819	2006/02/21-2025/01/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
50	防止擊穿的半導體元件的製造方法	I250580	2006/03/01-2024/11/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
51	非揮發性記憶體的製造方法	I256109	2006/06/01-2025/03/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
52	非揮發性記憶體的製造方法	I256704	2006/06/11-2025/03/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
53	半導體元件的製造方法	I256701	2006/06/11-2025/05/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
54	導線的製造方法	I263288	2006/10/01-2025/07/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
55	非揮發性記憶體及其製造方法	I263310	2006/10/01-2025/09/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
56	單次可程式化唯讀記憶體及其操作方法	I266417	2006/11/11-2024/11/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
57	快閃記憶體的製造方法	I269411	2006/12/21-2025/08/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
58	針測裝置及系統	I269399	2006/12/21-2025/11/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
59	動態隨機存取記憶體及其製造方法	I282164	2007/06/01-2025/06/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
60	廢氣排放裝置及半導體製程設備	I296818	2008/05/11-2026/03/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
61	浮置閘極與非揮發性記憶體的製造方法	I296837	2008/05/11-2026/06/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
62	非揮發性記憶體與半導體元件的製造方法	I297199	2008/05/21-2026/01/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
63	製程裝置排水回收系統及方法	I297326	2008/06/01-2023/03/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
64	字元線的形成方法與非揮發性記憶體的製造方法	I297533	2008/06/01-2026/03/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
65	應用於半導體製造之品質控制的虛擬量測預估方法與系統	I297506	2008/06/01-2026/06/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
66	非揮發性記憶體的製造方法	I297929	2008/06/11-2026/03/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
67	調整機台設定的方法、製造控制系統、及半導體製造系統	I298431	2008/07/01-2025/06/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
68	回溯記憶晶片在其母晶圓中之原位置的方法及系統	I298884	2008/07/11-2026/05/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
69	適用於半導體晶圓製造的設備校正系統與方法	I298900	2008/07/11-2026/06/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
70	靜電夾盤之使用壽命的預測方法	I298787	2008/07/11-2026/03/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
71	缺陷分類檢測方法與系統	I299538	2008/08/01-2026/06/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
72	氣體採樣裝置	I299786	2008/08/11-2026/04/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
73	非揮發性記憶體及其製造方法	I299911	2008/08/11-2026/03/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
74	隔離機台排水回收污染源之方法與系統	I300057	2008/08/21-2025/07/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
75	浮置閘極與非揮發性記憶體之製造方法	I300260	2008/08/21-2026/07/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
76	單次可程式記憶體及其製造方法	I300620	2008/09/01-2026/06/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
77	晶圓缺陷管理方法	I300887	2008/09/11-2024/06/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
78	機械手臂之無線三維位移校正系統	I301441	2008/10/01-2026/06/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
79	拋光墊及其製造方法	I301438	2008/10/01-2026/07/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
80	半導體結構與非揮發性記憶體的製造方法,以及非揮發性記憶體結構	I302021	2008/10/11-2026/06/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
81	形成氮化鈦膜的方法	I302351	2008/10/21-2022/10/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
82	電容量測之信號產生電路	I302202	2008/10/21-2026/07/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
83	反及閘型非揮發性記憶體及其製造方法與操作方法	I302741	2008/11/01-2026/06/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
84	物流設備及其感測裝置	I303465	2008/11/21-2026/04/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
85	半導體生產之派工整合系統及進行派工的方法	I304185	2008/12/11-2025/12/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
86	介電層的製造方法	I304231	2008/12/11-2026/07/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
87	非揮發性記憶體的製造方法	I304252	2008/12/11-2026/07/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
88	半導體製造之案件管理方法	I304557	2008/12/21-2022/03/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
89	非揮發性記憶體的製造方法	I304641	2008/12/21-2026/06/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
90	光導體覆主動像素感測器	I305059	2009/01/01-2026/07/17	發明	臺灣	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
91	塗佈設備及其防止接頭未拔取的裝置	I305503	2009/01/21-2026/09/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
92	半導體製造之批次控制方法與系統	I305875	2009/02/01-2025/12/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
93	影像感測器結構及其製造方法	I306307	2009/02/11-2026/09/27	發明	臺灣	邏輯 IC
94	影像感測器結構及其製造方法	I320577	2010/02/11-2026/09/19	發明	臺灣	邏輯 IC
95	具有電容器的半導體元件及其製造方法	I324389	2010/05/01-2026/09/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
96	影像感測器及其製作方法	I325634	2010/06/01-2026/11/22	發明	臺灣	邏輯 IC
97	自行對準接觸窗及其製造方法	I330398	2010/09/11-2027/01/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
98	降低加熱電極與相變化材料層間接觸面積之方法、相變化記憶裝置及其製造方法	I333273	2010/11/11-2027/05/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
99	影像感測器及其製作方法	I333692	2010/11/21-2027/02/04	發明	臺灣	邏輯 IC
100	瓶身鎖定裝置以及液體管理系統及其方法	I344669	2011/07/01-2027/06/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
101	含氟廢水之處理方法與廢水處理系統	I352069	2011/11/11-2028/01/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
102	存取非揮發性記憶體中資料的方法	I357080	2012/01/21-2028/02/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
103	積體電路與放電電路	I358067	2012/02/11-2027/12/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
104	非揮發性記憶體及其製造方法	I360203	2012/03/11-2027/10/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
105	決定非揮發性記憶體中錯誤更正碼區塊之位元數的方法	I360048	2012/03/11-2028/04/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
106	製作快閃記憶體的方法	I372448	2012/09/11-2027/08/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
107	自動化物料搬運系統及方法	I373090	2012/09/21-2028/09/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
108	承載裝置及沉積機台的監測方法	I377639	2012/11/21-2028/07/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
109	測量曝光機台之數值孔徑的方法、控片、光罩與監控曝光機台之數值孔徑的方法	I377450	2012/11/21-2028/11/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
110	取樣裝置與取樣方法	I380010	2012/12/21-2028/11/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
111	微機電系統結構及其製造方法	I388496	2013/03/11-2030/01/11	發明	臺灣	邏輯 IC
112	動態隨機存取記憶體之冠狀電容器的製程及結構	I397976	2013/06/01-2029/05/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
113	記憶體裝置以及資料讀取方法	I404076	2013/08/01-2028/01/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
114	非揮發性記憶體	I404195	2013/08/01-2029/10/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
115	非揮發性半導體記憶裝置用的分頁緩衝電路及其控制方法	I415131	2013/11/11-2029/11/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
116	具有垂直通道電晶體的動態隨機存取記憶胞及陣列	I415247	2013/11/11-2030/12/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
117	非揮發性記憶體及其製造方法	I415248	2013/11/11-2029/10/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
118	相變化記憶裝置及其製造方法	I418027	2013/12/01-2028/11/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
119	止回閥及真空系統	I420039	2013/12/21-2031/02/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
120	非揮發性記憶體元件及其製造方法	I422017	2014/01/01-2031/04/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
121	非揮發性半導體記憶裝置及其寫入方法	I426516	2014/02/11-2029/10/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
122	非揮發性半導體記憶裝置及其讀取方法	I426518	2014/02/11-2029/12/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
123	監控微影製程之方法與監控標記	I432915	2014/04/01-2028/04/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
124	風扇模組	I432943	2014/04/01-2028/12/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
125	非揮發性半導體記憶裝置	I433155	2014/04/01-2029/12/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
126	結合紅外線感測之環境光源感測器及其製造方法	I438917	2014/05/21-2029/11/11	發明	臺灣	邏輯 IC
127	動態隨機存取記憶體的電容器下電極的製造方法	I440166	2014/06/01-2030/08/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
128	用於 NAND 快閃記憶體技術領域的寫入方法	I451416	2014/09/01-2029/12/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
129	垂直通道電晶體陣列及其製造方法	I458068	2014/10/21-2030/08/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
130	垂直通道電晶體陣列及其製造	I469323	2015/01/11-2031/03/14	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	方法					生產製程
131	接觸窗開口的形成方法	I473205	2015/02/11-2031/11/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
132	電阻式記憶體結構及其製作方法	I473262	2015/02/11-2032/10/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
133	內部電壓調整電路、內部電壓調整方法以及半導體裝置	I482164	2015/04/21-2033/01/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
134	非揮發性半導體記憶裝置及其讀出方法	I482159	2015/04/21-2032/12/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
135	承載治具	I481737	2015/04/21-2034/08/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
136	半導體結構的製造方法	I485811	2015/05/21-2032/07/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
137	立體垂直式記憶體的製作方法	I488265	2015/06/11-2032/07/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
138	一種半導體線路製程	I488238	2015/06/11-2032/03/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
139	半導體結構及其製造方法	I490982	2015/07/01-2031/08/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
140	非揮發性半導體記憶裝置及其寫入方法	I496152	2015/08/11-2032/07/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
141	半導體記憶裝置及其 ID 碼及上位位址寫入方法	I496153	2015/08/11-2032/07/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
142	光感測器	I505455	2015/10/21-2033/09/26	發明	臺灣	邏輯 IC
143	非揮發性記憶體及其製造方法	I506768	2015/11/01-2030/12/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
144	爐管製程的派工控制方法	I506702	2015/11/01-2034/07/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
145	穿透式電子顯微鏡試片的製備方法	I506262	2015/11/01-2034/08/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
146	垂直式無電容ＤＲＡＭ記憶胞、ＤＲＡＭ陣列及其操作方法	I517307	2016/01/11-2031/08/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
147	一種半導體線路結構暨其製程	I517247	2016/01/11-2032/04/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
148	位準移位電路以及利用位準移位電路之半導體裝置	I517579	2016/01/11-2032/11/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
149	非揮發性半導體記憶裝置及其	I517168	2016/01/11-2033/05/22	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	讀出方法					生產製程
150	非揮發性記憶體裝置	I517166	2016/01/11-2033/11/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
151	結合紅外線感測功能之多波段光感測器及其製造方法	I517370	2016/01/11-2033/09/08	發明	臺灣	邏輯 IC
152	高壓靴帶式閘極驅動裝置	I521847	2016/02/11-2034/04/28	發明	臺灣	邏輯 IC
153	非揮發性記憶體及其製作方法	I525752	2016/03/11-2033/03/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
154	非揮發性半導體儲存裝置以及其控制方法	I525626	2016/03/11-2034/04/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
155	電源供應系統及電子裝置的維修方法	I525961	2016/03/11-2034/04/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
156	電阻式隨機存取記憶體	I531100	2016/04/21-2034/02/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
157	記憶體線路結構以及其半導體線路製程	I531032	2016/04/21-2033/11/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
158	晶片可靠度的測試板及其測試系統	I530702	2016/04/21-2034/12/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
159	負基準電壓產生電路及負基準電壓產生系統	I541628	2016/07/11-2035/01/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
160	三維記憶體的陣列結構及其製造方法	I542055	2016/07/11-2034/08/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
161	自動化資源傳送裝置及傳送方法	I541751	2016/07/11-2034/10/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
162	光阻回收系統及其方法	I547772	2016/09/01-2034/09/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
163	非揮發性記憶體及其製作方法	I548064	2016/09/01-2035/02/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
164	半導體裝置的製作方法	I548039	2016/09/01-2035/03/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
165	影像感測器及其製作方法	I548075	2016/09/01-2035/05/27	發明	臺灣	邏輯 IC
166	化學機械研磨裝置與方法	I547348	2016/09/01-2035/08/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
167	溝渠式橫向擴散金屬氧化半導體元件及其製造方法	I548086	2016/09/01-2035/03/11	發明	臺灣	邏輯 IC
168	介層窗製程用的溝填處理方法	I550769	2016/09/21-2035/01/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
169	曝光機台的遮光裝置	I550362	2016/09/21-2034/09/21	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
170	半導體晶圓、半導體晶片以及半導體裝置及其製造方法	I550749	2016/09/21-2035/01/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
171	影像感應器	I550842	2016/09/21-2035/04/08	發明	臺灣	邏輯 IC
172	半導體元件的製造方法	I550716	2016/09/21-2035/07/07	發明	臺灣	邏輯 IC
173	快閃記憶體裝置及其程式化動作的初始化方法	I550616	2016/09/21-2035/07/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
174	自動監控膜厚均勻性的方法	I550750	2016/09/21-2035/06/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
175	晶圓級動態預燒測試方法	I550293	2016/09/21-2035/09/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
176	NOR 型快閃記憶體及其製造方法	I555131	2016/10/21-2034/03/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
177	半導體元件及其製作方法	I555120	2016/10/21-2034/10/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
178	非揮發性記憶體的製造方法	I555065	2016/10/21-2034/12/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
179	快閃記憶體閘極結構及其製作方法	I555213	2016/10/21-2034/09/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
180	電阻式隨機存取記憶體結構及電阻式隨機存取記憶體的操作方法	I555246	2016/10/21-2034/11/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
181	動態記憶體測試裝置及其測試方法	I559009	2016/11/21-2034/12/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
182	隔離結構及具有其之非揮發性記憶體的製造方法	I555179	2016/10/21-2035/02/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
183	圖案化方法	I555082	2016/10/21-2035/05/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
184	半導體元件的製作方法	I555066	2016/10/21-2035/05/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
185	記憶體結構及其操作方法	I559450	2016/11/21-2034/04/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
186	快閃記憶體及其製造方法	I559459	2016/11/21-2034/12/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
187	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I559585	2016/11/21-2034/10/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
188	內部電源電壓產生電路、半導體記憶裝置及半導體裝置	I559308	2016/11/21-2035/05/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
189	半導體結構的製造方法	I559370	2016/11/21-2035/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
190	非揮發性記憶體的製造方法	I559455	2016/11/21-2035/01/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
191	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I559586	2016/11/21-2034/12/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
192	負基準電壓產生電路	I559114	2016/11/21-2035/08/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
193	半導體晶圓的金屬汙染即時監控方法	I559424	2016/11/21-2035/03/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
194	浮置閘極與非揮發性記憶胞的製造方法	I559456	2016/11/21-2035/06/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
195	快閃記憶體的製作方法	I566294	2017/01/11-2034/10/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
196	晶圓傳送盒搬運方法、橋接儲存器、以及控制裝置	I566316	2017/01/11-2034/12/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
197	非揮發性記憶體及其製造方法	I566381	2017/01/11-2034/12/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
198	能改善像素動態範圍的 CMOS 影像感應器	I566390	2017/01/11-2034/10/30	發明	臺灣	邏輯 IC
199	一種爐管製程的派工控制方法	I566064	2017/01/11-2035/06/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
200	靜態隨機存取記憶體	I566335	2017/01/11-2035/10/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
201	製程控制方法與製程控制系統	I571908	2017/02/21-2034/08/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
202	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I572073	2017/02/21-2034/09/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
203	曝光機台對準光源裝置內的模組作動監控方法及監控系統	I571710	2017/02/21-2034/12/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
204	非揮發性記憶體的製造方法	I571973	2017/02/21-2034/12/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
205	靜態隨機存取記憶體與其製造方法	I571968	2017/02/21-2034/11/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
206	半導體結構及其製造方法	I572016	2017/02/21-2035/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
207	半導體電晶體與快閃記憶體及其製造方法	I571974	2017/02/21-2035/05/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
208	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I572074	2017/02/21-2035/02/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
209	偵測微影熱點的方法	I571701	2017/02/21-2035/04/29	發明	臺灣	邏輯 IC
210	非揮發性記憶體	I572014	2017/02/21-2035/01/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
211	電壓產生電路、調節器電路、半導體記憶裝置及半導體裝置	I572135	2017/02/21-2035/08/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
212	靜態隨機存取記憶體及其製造方法	I571970	2017/02/21-2035/10/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
213	CMOS 影像感測單元及其製造方法	I572023	2017/02/21-2035/04/14	發明	臺灣	邏輯 IC
214	半導體元件及其製造方法	I572024	2017/02/21-2035/07/05	發明	臺灣	邏輯 IC
215	快閃記憶體裝置及資料抹除方法	I571879	2017/02/21-2035/07/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
216	半導體元件及其製造方法	I571938	2017/02/21-2035/10/14	發明	臺灣	邏輯 IC
217	橫向擴散金屬氧化半導體元件及其製造方法	I571939	2017/02/21-2036/01/19	發明	臺灣	邏輯 IC
218	非揮發性半導體記憶裝置與寫入方法	I581268	2017/05/01-2035/04/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
219	非揮發性記憶體及其製造方法	I581373	2017/05/01-2035/02/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
220	半導體記憶裝置	I581262	2017/05/01-2035/07/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
221	影像感測元件的光管的製造方法	I581413	2017/05/01-2035/07/16	發明	臺灣	邏輯 IC
222	物品缺陷檢測方法、影像處理系統與電腦可讀取記錄媒體	I581213	2017/05/01-2035/12/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
223	多層王冠型金屬-絕緣體-金屬電容器結構及其製作方法	I581441	2017/05/01-2035/09/07	發明	臺灣	邏輯 IC
224	電壓校正電路及電壓校正系統	I580984	2017/05/01-2035/10/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
225	半導體元件及其製作方法	I581428	2017/05/01-2035/12/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
226	曝光裝置與曝光方法	I581072	2017/05/01-2035/11/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
227	記憶體的製造方法	I581407	2017/05/01-2036/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
228	提升圖案精密度的方法	I585512	2017/06/01-2035/03/11	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
229	半導體裝置之控制電路及其方法	I585767	2017/06/01-2035/09/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
230	半導體記憶裝置及半導體積體電路裝置	I585772	2017/06/01-2035/07/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
231	非揮發性記憶裝置與用於非揮發性記憶裝置的寫入電路及方法	I585768	2017/06/01-2035/09/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
232	電容器結構及其製造方法	I585795	2017/06/01-2035/05/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
233	隨機動態記憶體晶片封裝結構	I585924	2017/06/01-2035/11/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
234	止逆閥及防止氣體回沖的系統	I585323	2017/06/01-2035/11/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
235	記憶體結構	I585951	2017/06/01-2035/12/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
236	相移式光罩及其製造方法	I585510	2017/06/01-2036/02/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
237	內部電源電壓輔助電路、半導體記憶裝置及半導體裝置	I592936	2017/07/21-2035/06/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
238	電晶體測試電路及方法、半導體記憶裝置以及半導體裝置	I592939	2017/07/21-2035/08/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
239	金屬氧化物金屬電容器電路及其半導體裝置	I593075	2017/07/21-2035/12/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
240	影像感測器	I593290	2017/07/21-2035/07/29	發明	臺灣	邏輯 IC
241	用於非揮發性記憶裝置的感測電路以及非揮發性記憶裝置	I592940	2017/07/21-2035/12/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
242	半導體元件及其製造方法	I593093	2017/07/21-2035/12/21	發明	臺灣	邏輯 IC
243	非揮發性記憶體及其操作方法	I593062	2017/07/21-2036/06/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
244	半導体記憶裝置	I592941	2017/07/21-2036/05/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
245	結構上的光阻圖案製程	I592759	2017/07/21-2036/06/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
246	電容器結構及其製造方法	I593120	2017/07/21-2036/07/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
247	衡量二元資料於時間等級的群聚級別的無母數分析方法	I592810	2017/07/21-2036/08/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
248	半導體裝置、測試裝置及測試系統	I598602	2017/09/11-2035/11/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
249	非揮發性半導體記憶裝置及其抹除方法	I598880	2017/09/11-2036/09/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
250	影像感測器及其製作方法	I599028	2017/09/11-2036/10/13	發明	臺灣	邏輯 IC
251	電阻式隨機存取記憶體結構	I603512	2017/10/21-2035/07/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
252	鎖存電路以及半導體記憶裝置	I603328	2017/10/21-2036/09/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
253	化學機械研磨之固定環	I602650	2017/10/21-2036/07/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
254	揮發性半導體記憶裝置、其再新控制電路及方法	I608480	2017/12/11-2036/05/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
255	半導體記憶裝置及其位址控制方法	I608478	2017/12/11-2036/09/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
256	自刷新控制裝置以及揮發性半導體記憶裝置	I608479	2017/12/11-2036/08/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
257	半導體記憶裝置	I608481	2017/12/11-2037/01/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
258	影像感測器及其製作方法	I608600	2017/12/11-2036/08/03	發明	臺灣	邏輯 IC
259	自動化晶圓交換系統以及其流程外的晶圓置換方法	I615912	2018/02/21-2035/02/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
260	壓力檢測裝置、過濾器監控系統、檢測過濾器之過濾效能之方法以及檢測是否可拆卸過濾器之方法	I615189	2018/02/21-2036/08/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
261	半導體元件	I615979	2018/02/21-2036/08/31	發明	臺灣	邏輯 IC
262	影像感測器及其製作方法	I615957	2018/02/21-2036/08/28	發明	臺灣	邏輯 IC
263	記憶體裝置	I615854	2018/02/21-2036/12/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
264	MIM 電容之結構及其製造方法	I622176	2018/04/21-2035/12/03	發明	臺灣	邏輯 IC
265	半導體元件的製造方法	I622169	2018/04/21-2037/02/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
266	影像感測器及其製作方法	I622165	2018/04/21-2037/03/05	發明	臺灣	邏輯 IC
267	記憶體結構及其製作方法	I622133	2018/04/21-2037/05/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
268	非揮發性記憶體及其存取方法	I622052	2018/04/21-2037/02/23	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
269	雙位元快閃記憶體記憶體結構及其製造方法	I627732	2018/06/21-2035/02/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
270	垂直式記憶體及其製作方法	I627711	2018/06/21-2037/06/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
271	影像亮度重配模組及影像亮度重配方法	I627440	2018/06/21-2037/05/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
272	半導體元件及其製造方法	I633660	2018/08/21-2037/05/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
273	快閃記憶體裝置及其更新方法	I633553	2018/08/21-2037/03/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
274	穩壓輸出裝置	I633408	2018/08/21-2037/08/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
275	統計多維變數而推算生產力的方法、統計多維變數而排程優先順序的方法與統計多維變數進行最佳化配置的方法	I639925	2018/11/01-2037/08/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
276	非揮發性記憶體裝置及對其驗證的錯誤補償方法	I640011	2018/11/01-2037/10/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
277	光罩承載平台的維護方法	I639886	2018/11/01-2037/10/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
278	積體電路晶片及其檢查方法	I639847	2018/11/01-2037/06/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
279	相移式光罩及其製作方法	I639884	2018/11/01-2037/11/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
280	非依電性儲存裝置、非依電性記憶體積體電路及其非依電性記憶體的操作方法	I651727	2019/02/21-2037/06/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
281	非揮發性記憶體結構及防止其產生程式化干擾的方法	I651835	2019/02/21-2037/03/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
282	積體電路結構及其製造方法	I651837	2019/02/21-2038/02/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
283	靜態隨機存取記憶體裝置、其冗餘電路及半導體裝置	I651729	2019/02/21-2038/05/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
284	METHOD FOR MANUFACTURING MEMORY DEVICE	6551877	2003/04/22-2022/06/11	發明	美國	DRAM 生產製程
285	EXHAUST GAS PROCESSING	6605141	2003/08/12-2023/03/17	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	APPARATUS					生產製程
286	STRUCTURE, FABRICATION AN OPERATION METHOD OF FLASH MEMORY DEVICE	6628550	2003/09/30-2022/06/14	發明	美國	DRAM 生產製程
287	METHOD OF FABRICATING FLASH MEMORY	6635533	2003/10/21-2023/03/27	發明	美國	DRAM 生產製程
288	METHOD FOR READING FLASH MEMORY WITH SILICON-OXIDE/NITRIDE/OXIDE-SILICON(SONOS) STRUCTURE	6639836	2003/10/28-2022/10/31	發明	美國	DRAM 生產製程
289	MEMORY DEVICE STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	6642111	2003/11/04-2022/07/09	發明	美國	DRAM 生產製程
290	SINGLE POLY EPROM AND METHOD FOR FORMING THE SAME	6653183	2003/11/25-2022/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
291	METHOD OF CLEANING A PROBE CARD	6659847	2003/12/09-2022/08/28	發明	美國	DRAM 生產製程
292	METHOD OF FABRICATING MEMORY DEVICE	6696350	2004/02/24-2022/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程
293	MANUFACTURING METHOD OF FLASH MEMORY	6706602	2004/03/16-2022/09/20	發明	美國	DRAM 生產製程
294	STRUCTURE OF FLASH MEMORY DEVICE AND FABRICATION METHOD THEREOF	6730959	2004/05/04-2022/10/30	發明	美國	DRAM 生產製程
295	NON-VOLATILE MEMORY CELL STRUCTURE AND METHOD FOR MANUFACTURING THEREOF	6737700	2004/05/18-2023/05/13	發明	美國	DRAM 生產製程
296	AUTOMATIC TRANSPORTING SYSTEM AND METHOD FOR OPERATING THE SAME	6745102	2004/06/01-2023/04/10	發明	美國	DRAM 生產製程
297	DUAL-BIT NITRIDE READ	6757208	2004/06/29-2023/09/22	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	ONLY MEMORY CELL WITH PARASISTIC AMPLIFILER AND METHODS OF FABRICATING AND READING THE SAME					生產製程
298	AUTOMATIC PRODUCTION QUALITY CONTROL METHOD AND SYSTEM	6766208	2004/07/20-2022/10/24	發明	美國	DRAM 生產製程
299	FLASH MEMORY WITH SELF-ALIGNED SPLIT GATE AND METHODS FOR FABRICATING AND FOR OPERATING THE SAME	6765260	2004/07/20-2023/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
300	SEMICONDUCTOR AUTOMATION SYSTEM FOR A DAILY CHECK AND METHOD THEREOF	6766213	2004/07/20-2023/04/22	發明	美國	DRAM 生產製程
301	SPLIT GATE FLASH MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6768162	2004/07/27-2023/08/05	發明	美國	DRAM 生產製程
302	STRUCTURE, FABRICATION METHOD AND OPERATION METHOD OF FLASH MEMORY	6770925	2004/08/03-2023/03/07	發明	美國	DRAM 生產製程
303	FLASH MEMORY DEVICE STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6770934	2004/08/03-2023/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
304	FLASH MEMORY STRUCTURE AND OPERATING METHOD THEREOF	6774428	2004/08/10-2023/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
305	STRUCTURE, FABRICATION METHOD AND OPERATING METHOD FOR FLASH MEMORY	6778438	2004/08/17-2022/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
306	MEMORY DEVICES	6791136	2004/09/14-2022/07/09	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING THA SAME					生產製程
307	SPLIT-GATE FLASH MEMORY STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURE	6794710	2004/09/21-2022/08/27	發明	美國	DRAM 生產製程
308	METHOD FOR DETECTING DEFECT OF SEMICONDUCTOR DEVICE	6806104	2004/10/19-2023/09/25	發明	美國	DRAM 生產製程
309	SPUTTERING APPARATUS AND MANUFACTURING METHOD OF METAL LAYER/METAL COMPOUND LAYER BY USING THEREOF	6811662	2004/11/02-2023/08/22	發明	美國	DRAM 生產製程
310	METHOD OF FORMING FLOATING GATE OF MEMORY DEVICE	6812120	2004/11/02-2024/02/26	發明	美國	DRAM 生產製程
311	FLASH MEMORY CELL	6815758	2004/11/09-2023/08/22	發明	美國	DRAM 生產製程
312	SPLIT GATE FLASH MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6821849	2004/11/23-2023/08/05	發明	美國	DRAM 生產製程
313	STRUCTURE, FABRICATION METHOD AND OPERATING METHOD FOR FLASH MEMORY	6834011	2004/12/21-2022/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
314	FLASH MEMORY WITH SELF-ALIGNED SPLIT GATE AND METHODS FOR FABRICATING AND FOR OPERATING THE SAME	6838343	2005/01/04-2023/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
315	FRONT OPENING UNIFIED POD AND ASSOCIATED METHOD FOR PREVENTING OUTGASSING POLLUTION	6843833	2005/01/18-2023/06/16	發明	美國	DRAM 生產製程
316	FABRICATION METHOD OF A FLASH MEMORY DEVICE	6855599	2005/02/15-2022/10/30	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
317	FLASH MEMORY CELL INCLUDING TWO FLOATING GATES AND AN ERASING GATE	6855598	2005/02/15-2023/04/07	發明	美國	DRAM 生產製程
318	MANAGEMENT SYSTEM OF MONITOR WAFERS	6865434	2005/03/08-2023/12/25	發明	美國	DRAM 生產製程
319	SPLIT-GATE FLASH MEMORY STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURE	6867099	2005/03/15-2022/08/27	發明	美國	DRAM 生產製程
320	TRENCH FLASH MEMORY DEVICE AND METHOD OF FABRICATING THEREOF	6870212	2005/03/22-2023/02/05	發明	美國	DRAM 生產製程
321	METHOD FOR MANUFACTURING NON-VOLATILE MEMORY CELL	6869842	2005/03/22-2023/05/13	發明	美國	DRAM 生產製程
322	METHOD OF MANUFACTURING HIGH COUPLING RATIO FLASH MEMORY HAVING SIDEWALL SPACER FLOATING GATE ELECTRODE	6875660	2005/04/05-2023/05/29	發明	美國	DRAM 生產製程
323	RETICLE TRANSFERRING SUPPORT AND TRANSFERRING METHOD THEREOF	6882408	2005/04/19-2023/06/25	發明	美國	DRAM 生產製程
324	METHOD FOR FORMING A TITANIUM NITRIDE LAYER	6893963	2005/05/17-2023/04/20	發明	美國	DRAM 生產製程
325	METHOD OF FABRICATING A FLASH MEMORY	6893918	2005/05/17-2024/05/19	發明	美國	DRAM 生產製程
326	METHOD OF ANALYZING FINAL TEST PARAMETERS	6898539	2005/05/24-2023/08/29	發明	美國	DRAM 生產製程
327	SPLIT GATE FLASH MEMORY CELL	6897521	2005/05/24-2023/09/15	發明	美國	DRAM 生產製程
328	COMPLEX MULTIVARIATE ANALYSIS SYSTEM AND METHOD	6904384	2005/06/07-2023/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
329	FLASH MEMORY CELL, FLASH MEMORY CELL ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6911690	2005/06/28-2023/08/19	發明	美國	DRAM 生產製程
330	WAFER GRINDING APPARATUS	6910956	2005/06/28-2023/12/22	發明	美國	DRAM 生產製程
331	FLASH MEMORY STRUCTURE AND OPERATING METHOD THEREOF	6914826	2005/07/05-2023/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
332	FLASH MEMORY DEVICE STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	6913974	2005/07/05-2023/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
333	SUPPORT STAND	6914732	2005/07/05-2024/08/08	發明	美國	DRAM 生產製程
334	DUMMY PROCESS AND POLISHING-PAD CONDITIONING PROCESS FOR CHEMICAL MECHANICAL POLISHING APPARATUS	6913516	2005/07/05-2024/07/16	發明	美國	DRAM 生產製程
335	SINGLE POLY EPROM AND METHOD FOR FORMING THE SAME	6917070	2005/07/12-2022/10/24	發明	美國	DRAM 生產製程
336	METHOD OF STABLIZING MATERIAL LAYER	6919102	2005/07/19-2023/07/08	發明	美國	DRAM 生產製程
337	METHOD OF SAMPLING CONTAMINANTS OF A SEMICONDUCTOR WAFER CARRIER	6923188	2005/08/02-2023/05/13	發明	美國	DRAM 生產製程
338	SONOS MULTI-LEVEL MEMORY CELL	6943404	2005/09/13-2023/08/05	發明	美國	DRAM 生產製程
339	METHOD AND RELATED SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR EQUIPEMENT PREVENTION	6950783	2005/09/27-2024/03/26	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	MAINTENANCE MANAGEMENT					
340	FLASH MEMORY CELL STRUCTURE	6963105	2005/11/08-2023/10/29	發明	美國	DRAM 生產製程
341	AUTO-RECOVERY WAFER TESTING APPARATUS AND WAFER TESTING METHOD	6963213	2005/11/08-2024/07/28	發明	美國	DRAM 生產製程
342	METHOD FOR ANALYZING WAFER TEST PARAMETERS	6968280	2005/11/22-2023/07/08	發明	美國	DRAM 生產製程
343	METHOD OF FABRICATING FLASH MEMORY CELL	6972260	2005/12/06-2024/05/07	發明	美國	DRAM 生產製程
344	METHOD OF FABRICATING A FLASH MEMORY	6984559	2006/01/10-2024/05/27	發明	美國	DRAM 生產製程
345	METHOD AND RELATED SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR EQUIPMENT EARLY WARNING MANAGEMENT	6999897	2006/02/14-2024/03/28	發明	美國	DRAM 生產製程
346	NAND FLASH MEMORY CELL ROW	7005699	2006/02/28-2024/01/15	發明	美國	DRAM 生產製程
347	METHOD OF BUILDING A DEFECT DATABASE	7020536	2006/03/28-2024/02/06	發明	美國	DRAM 生產製程
348	METHOD OF FABRICATING A FLASH MEMORY CELL	7029973	2006/04/18-2023/03/13	發明	美國	DRAM 生產製程
349	ASEISMATIC DEVICE	7028433	2006/04/18-2024/06/11	發明	美國	DRAM 生產製程
350	CAPACITY MANAGEMENT SYSTEM AND METHOD	7035704	2006/04/25-2024/11/16	發明	美國	DRAM 生產製程
351	NON-VOLATILE MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7038267	2006/05/02-2024/04/30	發明	美國	DRAM 生產製程
352	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY CELL ADAPTED FOR INTEGRATION OF DEVICES AND FOR MULTIPLE READ/WRITE OPERATIONS	7049189	2006/05/23-2024/07/16	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
353	FLASH MEMORY CELL, FLASH MEMORY CELL ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7057940	2006/06/06-2023/08/19	發明	美國	DRAM 生產製程
354	METHOD OF MANUFACTURING NON-VOLATILE MEMORY CELL	7060560	2006/06/13-2024/09/23	發明	美國	DRAM 生產製程
355	P-CHANNEL NAND FLASH MEMORY AND OPERATING METHOD THEREOF	7061805	2006/06/13-2025/06/06	發明	美國	DRAM 生產製程
356	METHOD OF DEFECT REVIEW	7071011	2006/07/04-2024/02/05	發明	美國	DRAM 生產製程
357	METHOD FOR FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7071061	2006/07/04-2025/09/26	發明	美國	DRAM 生產製程
358	METHOD FOR MANUFACTURING ONE-TIME ELECTRICALLY PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY	7074674	2006/07/11-2025/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程
359	AUTOMATIC INTELLIGENT YIELD IMPROVING AND PROCESS PARAMETER MULTIVARIATE SYSTEM AND THE ANALYSIS METHOD THEREOF	7079677	2006/07/18-2025/03/15	發明	美國	DRAM 生產製程
360	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND METHOD OF MANFACTURING THE SAME	7091550	2006/08/15-2024/01/06	發明	美國	DRAM 生產製程
361	SEMICONDUCTOR PROCESS AND YIELD ANALYSIS INTEGRATED REAL-TIME MANAGEMENT METHOD	7099729	2006/08/29-2024/11/23	發明	美國	DRAM 生產製程
362	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	7102193	2006/09/05-2025/11/09	發明	美國	DRAM 生產製程
363	FLASH MEMORY CELL	7109082	2006/09/19-2024/12/21	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
364	MULTI-LEVEL MEMORY CELL AND FABRICATING METHOD THEREOF	7098109	2006/08/29-2023/08/05	發明	美國	DRAM 生產製程
365	METHOD OF FORMING BARRIER LAYER	7115214	2006/10/03-2024/05/13	發明	美國	DRAM 生產製程
366	METHOD OF APPLYING MICRO-PROTECTION IN DEFECT ANALYSIS	7115865	2006/10/03-2025/06/01	發明	美國	DRAM 生產製程
367	METHOD OF FABRICATING A PHOTOSENSITIVE STRUCTURE	7125738	2006/10/24-2024/10/14	發明	美國	邏輯 IC
368	INSPECTION METHODS FOR A SEMICONDUCTOR DEVICE	7132354	2006/11/07-2025/08/30	發明	美國	DRAM 生產製程
369	DEVICE AND METHOD FOR TESTING AN EXPOSURE APPARATUS	7145644	2006/12/05-2024/11/03	發明	美國	DRAM 生產製程
370	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7144774	2006/12/05-2025/08/29	發明	美國	DRAM 生產製程
371	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7148107	2006/12/12-2025/11/15	發明	美國	DRAM 生產製程
372	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD AND OPERATING METHOD THEREOF	7154142	2006/12/26-2025/06/21	發明	美國	DRAM 生產製程
373	MULTI-LEVEL MEMORY CELL	7164177	2007/01/16-2024/03/15	發明	美國	DRAM 生產製程
374	AUTO-RECOVERY WAFER TESTING APPARATUS AND WAFER TESTING METHOD	7164283	2007/01/16-2024/08/27	發明	美國	DRAM 生產製程
375	MANUFACTURING METHOD A FLASH MEMORY CELL ARRAY	7166513	2007/01/23-2023/08/19	發明	美國	DRAM 生產製程
376	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7166512	2007/01/23-2025/08/11	發明	美國	DRAM 生產製程
377	NON-VOLATILE MEMORY, NON-VOLATILE MEMORY	7180128	2007/02/20-2024/11/12	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF					
378	FLASH MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7183606	2007/02/27-2024/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
379	METHOD OF FLUORIDE-CONTAINING WASTEWATER TREATMENT	7182873	2007/02/27-2025/06/17	發明	美國	DRAM 生產製程
380	METHOD OF FABRICATING A NON-VOLATILE MEMORY	7183158	2007/02/27-2025/06/08	發明	美國	DRAM 生產製程
381	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	7183607	2007/02/27-2026/04/13	發明	美國	DRAM 生產製程
382	FLASH MEMORY CELL AND FABRICATING METHOD THEREOF	7192832	2007/03/20-2024/05/20	發明	美國	DRAM 生產製程
383	WAFER DEFECT DETECTION METHODS AND SYSTEMS	7193698	2007/03/20-2025/09/05	發明	美國	DRAM 生產製程
384	METHOD FOR MANUFACTURING ANTI-PUNCH THROUGH SEMICONDUCTOR DEVICE	7195982	2007/03/27-2025/10/12	發明	美國	DRAM 生產製程
385	FLASH MEMORY	7196371	2007/03/27-2025/08/25	發明	美國	DRAM 生產製程
386	METHOD OF OPERATING P-CHANNEL MEMORY	7200040	2007/04/03-2025/10/29	發明	美國	DRAM 生產製程
387	METHOD OF MANUFACTURING A DUAL BIT FLASH MEMORY	7205189	2007/04/17-2025/01/25	發明	美國	DRAM 生產製程
388	METHOD FOR FORMING TRENCH GATE DIELECTRIC LAYER	7205217	2007/04/17-2025/11/21	發明	美國	DRAM 生產製程
389	SPLIT GATE FLASH MEMORY	7208796	2007/04/24-2025/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
390	DISPATCH INTEGRATION SYSTEM AND METHOD BASED ON SEMICONDUCTOR	7218981	2007/05/15-2026/04/12	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	MANUFACTURING					
391	OPERATIONAL MODEL FOR SIMULATING MANUFACTURE FLOW AND SIMULATING METHOD THEREOF	7221994	2007/05/22-2025/06/23	發明	美國	DRAM 生產製程
392	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE AND NON-VOLATILE MEMORY	7226851	2007/06/05-2025/12/22	發明	美國	DRAM 生產製程
393	TOOL FOR REMOVING PARTICLES FROM RETICLE	7234196	2007/06/26-2025/06/18	發明	美國	DRAM 生產製程
394	SEMICONDUCTOR FACILITY	7235992	2007/06/26-2025/06/07	發明	美國	DRAM 生產製程
395	FLASH MEMORY CELL AND FABRICATING METHOD THEREOF	7235839	2007/06/26-2025/02/08	發明	美國	DRAM 生產製程
396	METHOD FOR FABRICATING CONDUCTIVE LINE	7235442	2007/06/26-2025/12/12	發明	美國	DRAM 生產製程
397	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	7235444	2007/06/26-2026/04/13	發明	美國	DRAM 生產製程
398	ERASING METHOD FOR NON-VOLATILE MEMORY	7239555	2007/07/03-2026/03/03	發明	美國	DRAM 生產製程
399	METHODS AND SYSTEMS FOR SEMICONDUCTOR DEFECT DETECTION	7254759	2007/08/07-2026/01/26	發明	美國	DRAM 生產製程
400	ION SAMPLING SYSTEM FOR WAFER	7255114	2007/08/14-2025/03/17	發明	美國	DRAM 生產製程
401	METHOD OF FORMING SI TIP BY SINGLE ETCHING PROCESS AND ITS APPLICATION FOR FORMING FLOATING GATE	7259051	2007/08/21-2025/09/10	發明	美國	DRAM 生產製程
402	REAL-TIME MANAGEMENT SYSTEMS AND METHODS FOR MANUFACTURING	7260444	2007/08/21-2025/09/19	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	MANAGEMENT AND YIELD RATE ANALYSIS INTEGRATION					
403	NAND FLASH MEMORY CELL ROW AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7262096	2007/08/28-2024/05/31	發明	美國	DRAM 生產製程
404	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD AND OPERATING METHOD THEREOF	7274062	2007/09/25-2026/01/24	發明	美國	DRAM 生產製程
405	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7285463	2007/10/23-2025/08/11	發明	美國	DRAM 生產製程
406	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7285450	2007/10/23-2026/01/19	發明	美國	DRAM 生產製程
407	METHODS FOR DETERMINING TOOL ASSIGNMENT PREFERENCE AND MANUFACTURING SYSTEMS USING THE SAME	7292903	2007/11/06-2026/05/11	發明	美國	DRAM 生產製程
408	PROGRAMMABLE AND ERASABLE DIGITAL SWITCH DEVICE AND FABRICATION METHOD AND OPERATING METHOD THEREOF	7291882	2007/11/06-2026/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程
409	PROBE APPARATUS	7298154	2007/11/20-2026/04/26	發明	美國	DRAM 生產製程
410	METHOD FOR FABRICATING A NONVOLATILE MEMORY CELL	7309632	2007/12/18-2027/04/13	發明	美國	DRAM 生產製程
411	METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE AND WIRE WITH SILICIDE	7316956	2008/01/08-2026/03/16	發明	美國	DRAM 生產製程
412	WIRELESS 3D AUTO-OFFSET SYSTEM FOR ROBOT ARMS	7321215	2008/01/22-2026/08/09	發明	美國	DRAM 生產製程
413	METHOD OF OPERATING FLASH MEMORY CELL	7336539	2008/02/26-2024/11/25	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
414	FABRICATING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY	7335559	2008/02/26-2025/08/29	發明	美國	DRAM 生產製程
415	FLASH MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7335940	2008/02/26-2026/03/24	發明	美國	DRAM 生產製程
416	METHOD OF MANUFACTURING NON-VOLATILE MEMORY	7341913	2008/03/11-2026/06/29	發明	美國	DRAM 生產製程
417	PIPE TRAP	7344579	2008/03/18-2025/05/26	發明	美國	DRAM 生產製程
418	METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE	7354851	2008/04/08-2025/12/07	發明	美國	DRAM 生產製程
419	A NON-VOLATILE MEMORY	7355241	2008/04/08-2026/02/26	發明	美國	DRAM 生產製程
420	SPLIT GATE FLASH MEMORY CELL AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7358134	2008/04/15-2024/09/27	發明	美國	DRAM 生產製程
421	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICES AND PLUG	7368373	2008/05/06-2026/05/05	發明	美國	DRAM 生產製程
422	DEVICE FOR PROCESSING DISCHARGING EXHAUST GAS	7377964	2008/05/27-2026/04/26	發明	美國	DRAM 生產製程
423	METHOD OF DEFECT INSPECTION	7382451	2008/06/03-2026/01/05	發明	美國	DRAM 生產製程
424	MASK MANAGEMENT METHOD AND BAR CODE READING APPARATUS THEREOF	7389930	2008/06/24-2026/08/11	發明	美國	DRAM 生產製程
425	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7391073	2008/06/24-2026/08/03	發明	美國	DRAM 生產製程
426	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING AND OPERATING METHOD	7391078	2008/06/24-2025/10/12	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	THEREOF					
427	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	7394126	2008/07/01-2026/04/26	發明	美國	DRAM 生產製程
428	PROCESS FOR REMOVING PARTICLES FROM RETICLE	7396418	2008/07/08-2024/05/07	發明	美國	DRAM 生產製程
429	NON-VOLATILE MEMORY	7397080	2008/07/08-2026/01/19	發明	美國	DRAM 生產製程
430	FABRICATING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY	7405124	2008/07/29-2026/05/08	發明	美國	DRAM 生產製程
431	PHOTOSENSITIVE DEVICE	7411276	2008/08/12-2025/01/04	發明	美國	邏輯 IC
432	METHOD OF MANAGING WAFER DEFECTS	7412090	2008/08/12-2026/06/29	發明	美國	DRAM 生產製程
433	METHOD OF MANUFACTURING WELL PICK-UP STRUCTURE OF NON-VOLATILE MEMORY	7429503	2008/09/30-2027/01/30	發明	美國	DRAM 生產製程
434	DATA TRACKING METHOD AND SYSTEM APPLIED IN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	7433750	2008/10/07-2026/12/21	發明	美國	DRAM 生產製程
435	WAFER MEASURING FIXTURE	7431260	2008/10/07-2026/08/12	發明	美國	DRAM 生產製程
436	FLASH MEMORY CELL STRUCTURE AND OPERATING METHOD THEREOF	7436707	2008/10/14-2025/08/10	發明	美國	DRAM 生產製程
437	DEVICE FOR TESTING AN EXPOSURE APPARATUS	7436489	2008/10/14-2023/06/29	發明	美國	DRAM 生產製程
438	ONE-TIME PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY AND OPERATING METHOD THEREOF	7436028	2008/10/14-2025/06/22	發明	美國	DRAM 生產製程
439	METHOD OF EVALUATING THE UNIFORMITY OF THE THICKNESS OF THE POLY-SILICON GATE LAYER	7435642	2008/10/14-2027/04/11	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
440	METHOD OF PIPING DEFECT DETECTION	7442561	2008/10/28-2027/02/09	發明	美國	DRAM 生產製程
441	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE	7442998	2008/10/28-2026/09/26	發明	美國	DRAM 生產製程
442	ANTI-PUNCH-THROUGH SEMICONDUCTOR DEVICE	7442980	2008/10/28-2026/04/26	發明	美國	DRAM 生產製程
443	FABRICATING METHOD OF A FLASH MEMORY CELL	7445999	2008/11/04-2025/11/11	發明	美國	DRAM 生產製程
444	METHOD FOR FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE	7445998	2008/11/04-2025/07/22	發明	美國	DRAM 生產製程
445	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7445993	2008/11/04-2026/08/17	發明	美國	DRAM 生產製程
446	NON-VOLATILE MEMORY	7446370	2008/11/04-2026/09/02	發明	美國	DRAM 生產製程
447	PROBE SYSTEM	7449902	2008/11/11-2026/04/20	發明	美國	DRAM 生產製程
448	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD AND OPERATING METHOD THEREOF	7452775	2008/11/18-2025/10/05	發明	美國	DRAM 生產製程
449	NONVOLATILE MEMORY	7462902	2008/12/09-2026/05/25	發明	美國	DRAM 生產製程
450	FABRICATING METHOD OF AN NON-VOLATILE MEMORY	7462537	2008/12/09-2026/05/30	發明	美國	DRAM 生產製程
451	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY	7485529	2009/02/03-2024/11/12	發明	美國	DRAM 生產製程
452	METHOD OF FABRICATING FLASH MEMORY CELL	7491607	2009/02/17-2024/11/25	發明	美國	DRAM 生產製程
453	ONE TIME PROGRAMMABLE MEMORY AND THE MANUFACTURING METHOD THEREOF	7491998	2009/02/17-2027/06/13	發明	美國	DRAM 生產製程
454	METHOD OF MANUFACTURING A SONOS MEMORY	7514311	2009/04/07-2024/07/28	發明	美國	DRAM 生產製程
455	MULTI-LEVEL NON-	7518912	2009/04/14-2027/07/10	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	VOLATILE MEMORY					生產製程
456	NON-VOLATILE MEMORY INCLUDING ASSIST GATE	7528438	2009/05/05-2026/12/11	發明	美國	DRAM 生產製程
457	METHOD OF MANUFACTURING PHOTODIODE	7575941	2009/08/18-2025/04/10	發明	美國	邏輯 IC
458	IMAGE SENSOR STRUCTURE WITH RECESSED SEPARATOR LAYER	7638799	2009/12/29-2027/02/15	發明	美國	邏輯 IC
459	OPERATING METHOD OF ONE-TIME PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY	7663904	2010/02/16-2025/08/03	發明	美國	DRAM 生產製程
460	IMAGE SENSOR AND FABRICATION METHOD THEREOF	7671385	2010/03/02-2028/04/25	發明	美國	邏輯 IC
461	IMAGE SENSOR AND FABRICATION METHOD THEREOF	7679157	2010/03/16-2026/11/14	發明	美國	邏輯 IC
462	MEMORY PROGRAMMING METHOD AND DATA ACCESS METHOD	7778087	2010/08/17-2029/03/23	發明	美國	DRAM 生產製程
463	PHASE CHANGE MEMORY DEVICES AND METHODS FOR FABRICATING THE SAME	7855378	2010/12/21-2028/02/04	發明	美國	DRAM 生產製程
464	METHOD FOR PROGRAMMING A MEMORY STRUCTURE	7855918	2010/12/21-2029/06/04	發明	美國	DRAM 生產製程
465	INTEGRATED CIRCUITS AND DISCHARGE CIRCUITS	7903470	2011/03/08-2029/07/10	發明	美國	DRAM 生產製程
466	JUNCTION-FREE NAND FLASH MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	7915660	2011/03/29-2029/05/19	發明	美國	DRAM 生產製程
467	MOBILE PHONE ACCESSING SYSTEM AND RELATED	7937072	2011/05/03-2030/01/15	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	STORAGE DEVICE					
468	PROCESS FOR FABRICATING CROWN CAPACITORS OF DRAM AND CAPACITOR STRUCTURE	7951668	2011/05/31-2029/04/13	發明	美國	DRAM 生產製程
469	METHOD FOR PROGRAMMING A MEMORY STRUCTURE	7952934	2011/05/31-2028/06/24	發明	美國	DRAM 生產製程
470	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND METHOD OF READING THE SAME	8068362	2011/11/29-2030/06/07	發明	美國	DRAM 生產製程
471	PAGE BUFFER CIRCUIT FOR ELECTRICALLY REWRITABLE NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND CONTROL METHOD	8081522	2011/12/20-2030/07/30	發明	美國	DRAM 生產製程
472	MEMORY DEVICE AND DATA READING METHOD	8131954	2012/03/06-2030/06/05	發明	美國	DRAM 生產製程
473	MCP0002-METHOD OF MEASURING NUMERICAL APERTURE OF EXPOSURE MACHINE, CONTROL WAFER, PHOTOMASK, AND METHOD OF MONITORING NUMERICAL APERTURE OF EXPOSURE MACHINE	8134708	2012/03/13-2030/04/29	發明	美國	DRAM 生產製程
474	TANK-LOCKING DEVICE, SYSTEM FOR MANAGING LIQUID SUPPLY AND METHOD USING THE SAME	8140184	2012/03/20-2031/01/20	發明	美國	DRAM 生產製程
475	MCP00018-METHOD FOR MANUFACTURING MICROELECTROMECHANICAL SYSTEM STRUCTURE	8163583	2012/04/24-2030/09/16	發明	美國	邏輯 IC
476	AUTOMATED MATERIAL	8219242	2012/07/10-2031/03/05	發明	美國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	HANDLING SYSTEM AND METHOD					生產製程
477	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY, AND THE METHOD THEREOF	8223541	2012/07/17-2030/08/24	發明	美國	DRAM 生產製程
478	PHASE CHANGE MEMORY DEVICES AND METHODS FOR FABRICATING THE SAME	8242034	2012/08/14-2027/10/01	發明	美國	DRAM 生產製程
479	VOLTAGE ADJUSTING CIRCUITS AND VOLTAGE ADJUSTING METHODS	8278952	2012/10/02-2031/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
480	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY	8279673	2012/10/02-2030/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
481	TANK-LOCKING DEVICE, SYSTEM FOR MANAGING LIQUID SUPPLY AND METHOD USING THE SAME	8311669	2012/11/13-2028/01/30	發明	美國	DRAM 生產製程
482	DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY CELL AND ARRAY HAVING VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR	8324682	2012/12/04-2031/02/17	發明	美國	DRAM 生產製程
483	IMAGE SENSOR AND FABRICATION METHOD THEREOF	8334164	2012/12/18-2027/11/23	發明	美國	邏輯 IC
484	VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	8390062	2013/03/05-2031/02/11	發明	美國	DRAM 生產製程
485	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	8421141	2013/04/16-2031/07/04	發明	美國	DRAM 生產製程
486	VERTICLE CAPACITORLESS DRAM CELL,DRAM ARRAY AND OPERATION OF THE SAME	8441053	2013/05/14-2031/08/25	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
487	METHOD OF MANUFACTURING A 3-D VERTICAL MEMORY	8470671	2013/06/25-2032/10/24	發明	美國	DRAM 生產製程
488	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	8502297	2013/08/06-2031/03/25	發明	美國	DRAM 生產製程
489	MICRO ELECTRONIC MECHANICAL SYSTEM STRUCTURE	8502328	2013/08/06-2030/03/11	發明	美國	邏輯 IC
490	MANUFACTURING METHOD OF VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR ARRAY	8536008	2013/09/17-2030/07/20	發明	美國	DRAM 生產製程
491	TANK-LOCKING DEVICE, SYSTEM FOR MANAGING LIQUID SUPPLY AND METHOD USING THE SAME	8539800	2013/09/24-2028/05/23	發明	美國	DRAM 生產製程
492	AMBIT LIGHT SENSOR WITH FUNCTION OF IR SENSING	8558177	2013/10/15-2031/06/22	發明	美國	邏輯 IC
493	PROGRAMMING METHOD FOR NAND FLASH MEMORY DEVICE TO REDUCE ELECTRONS IN CHANNELS	8599614	2013/12/03-2030/01/13	發明	美國	DRAM 生產製程
494	METHOD FOR FORMING CONTACT HOLE	8709946	2014/04/29-2032/06/20	發明	美國	DRAM 生產製程
495	METHOD OF FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY DEVICE	8722489	2014/05/13-2031/07/04	發明	美國	DRAM 生產製程
496	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND WRITE-IN METHOD THEREOF	8738836	2014/05/27-2031/03/30	發明	美國	DRAM 生產製程
497	FABRICATING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY	8741754	2014/06/03-2031/02/22	發明	美國	DRAM 生產製程
498	INTERNAL VOLTAGE TRIMMING CIRCUIT, METHOD THEREOF AND SEMICONDUCTOR CURCUIT	8754703	2014/06/17-2032/11/05	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	DEVICE COMPRISING THE SAME					
499	VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR ARRAY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	8786014	2014/07/22-2031/08/31	發明	美國	DRAM 生產製程
500	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND READOUT METHOD THEREOF	8824206	2014/09/02-2032/12/26	發明	美國	DRAM 生產製程
501	METHOD FOR FABRICATING BOTTOM ELECTRODE OF CAPACITORS OF DRAM	8846485	2014/09/30-2031/05/16	發明	美國	DRAM 生產製程
502	PROCESS FOR SEMICONDUCTOR CIRCUIT	8883636	2014/11/11-2033/01/26	發明	美國	DRAM 生產製程
503	METHOD OF FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	8895386	2014/11/25-2032/11/21	發明	美國	DRAM 生產製程
504	SEMICONDUCTOR STRUCTURE	8907395	2014/12/09-2032/06/10	發明	美國	DRAM 生產製程
505	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND FABRICATION METHOD THEREOF	8921819	2014/12/30-2033/02/13	發明	美國	DRAM 生產製程
506	METHOD OF FORMING SEMICONDUCTOR STRUCTURE	8,980,703	2015/03/17-2031/09/25	發明	美國	DRAM 生產製程
507	METHOD FOR FABRICATING RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY	8999809	2015/04/07-2032/11/13	發明	美國	DRAM 生產製程
508	NONVOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND WRITE-IN METHOD THEREOF	9064580	2015/06/23-2033/05/12	發明	美國	DRAM 生產製程
509	LEVEL SHIFT CIRCUIT AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING LEVEL SHIFT CIRCUIT	9076529	2015/07/07-2033/04/16	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
510	NONVOLATILE SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE AND CONTROL METHOD THEREOF	9076546	2015/07/07-2034/02/24	發明	美國	DRAM 生產製程
511	SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND WRITING METHOD OF ID CODES AND UPPER ADDRESSES	9082469	2015/07/14-2033/08/22	發明	美國	DRAM 生產製程
512	MULTI-WAVE BAND LIGHT SENSOR COMBINED WITH FUNCTION OF IR SENSING AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	9136301	2015/09/15-2030/09/26	發明	美國	邏輯 IC
513	LIGHT SENSOR	9142583	2015/09/22-2033/11/26	發明	美國	邏輯 IC
514	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND READING-OUT METHOD THEREFORE	9190158	2015/11/17-2033/11/04	發明	美國	DRAM 生產製程
515	SEMICONDUCTOR CIRCUIT STRUCTURE AND PROCESS OF MAKING THE SAME	9196623	2015/11/24-2034/01/12	發明	美國	DRAM 生產製程
516	PROGRAMMING METHOD FOR NAND FLASH MEMORY DEVICE TO REDUCE ELECTRONS IN CHANNELS	9214242	2015/12/15-2029/04/30	發明	美國	DRAM 生產製程
517	MEMORY CIRCUIT STRUCTURE AND SEMICONDUCTOR PROCESS FOR MANUFACTURING THE SAME	9245766	2016/01/26-2034/05/19	發明	美國	DRAM 生產製程
518	INTERNAL POWER VOLTAGE GENERATING CIRCUIT, SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE	9275749	2016/03/01-2035/05/21	發明	美國	DRAM 生產製程
519	IMAGE SENSOR AND MANUFACTURING METHOD	9276026	2016/03/01-2035/07/24	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	THEREOF					
520	NEGATIVE REFERENCE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT AND NEGATIVE REFERENCE VOLTAGE GENERATING SYSTEM USING THE SAME	9285821	2016/03/15-2034/10/14	發明	美國	DRAM 生產製程
521	SEMICONDUCTOR MEMORY APPARATUS AND SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT APPARATUS	9293227	2016/03/22-2035/07/13	發明	美國	DRAM 生產製程
522	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	9305977	2016/04/05-2034/12/25	發明	美國	DRAM 生產製程
523	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	9318703	2016/04/19-2034/12/08	發明	美國	DRAM 生產製程
524	METHOD OF FABRICATING FLASH MEMORY	9318396	2016/04/19-2035/04/22	發明	美國	DRAM 生產製程
525	GAP FILL TREATMENT FOR VIA PROCESS	9368396	2016/06/14-2035/04/21	發明	美國	DRAM 生產製程
526	HIGH VOLTAGE BOOTSTRAP GATE DRIVING APPARATUS	9379696	2016/06/28-2034/06/28	發明	美國	邏輯 IC
527	FLASH MEMORY APPARATUS AND DATA ERASING METHOD THEREOF	9384844	2016/07/05-2035/09/09	發明	美國	DRAM 生產製程
528	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9391271	2016/07/12-2035/03/27	發明	美國	DRAM 生產製程
529	CMOS IMAGE SENSOR UNIT AND METHOD FOR	9391115	2016/07/12-2035/06/16	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	FABRICATING THE SAME					
530	IMAGE SENSOR	9391107	2016/07/12-2035/04/29	發明	美國	邏輯 IC
531	MANUFACTURING METHOD OF STRIP-SHAPED CONDUCTIVE STRUCTURES AND NON-VOLATILE MEMORY CELL	9390931	2016/07/12-2035/07/30	發明	美國	DRAM 生產製程
532	SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE WITH ONO STACK	9397183	2016/07/19-2035/01/22	發明	美國	DRAM 生產製程
533	NEGATIVE REFERENCE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT AND SYSTEM THEREOF	9397562	2016/07/19-2035/05/21	發明	美國	DRAM 生產製程
534	METHOD OF MANUFACTURING ISOLATION STRUCTURE AND NON-VOLATILE MEMORY WITH THE ISOLATION STRUCTURE	9406784	2016/08/02-2035/04/21	發明	美國	DRAM 生產製程
535	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY STRUCTURE AND METHOD FOR OPERATING RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY	9419053	2016/08/16-2035/01/21	發明	美國	DRAM 生產製程
536	NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND WRITING METHOD THEREOF	9424934	2016/08/23-2035/02/18	發明	美國	DRAM 生產製程
537	FLASH MEMORY STRUCTURE AND METHOD OF MAKING THE SAME	9437600	2016/09/06-2035/04/14	發明	美國	DRAM 生產製程
538	NON-VOLATILE MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9437715	2016/09/06-2035/04/28	發明	美國	DRAM 生產製程
539	FLASH MEMORY APPARATUS AND INITIALIZATION METHOD FOR PROGRAMMING	9437311	2016/09/06-2035/08/31	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	OPERATION THEREOF					
540	MEMORY STRUCTRUE AND OPERATION METHOD THEREOF	9461156	2016/10/04-2034/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
541	PATTERNING METHOD	9460933	2016/10/04-2035/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
542	MANUFACTURING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY	9466605	2016/10/11-2035/01/21	發明	美國	DRAM 生產製程
543	METHOD OF FORMING STAIR-STEP STRUCTURE IN 3-D NON-VOLATILE MEMORY	9466522	2016/10/11-2035/03/12	發明	美國	DRAM 生產製程
544	RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	9478741	2016/10/25-2034/12/08	發明	美國	DRAM 生產製程
545	STATIC RANDOM ACCESS MEMORY AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9478552	2016/10/25-2035/05/08	發明	美國	DRAM 生產製程
546	MOM CAPACITOR CIRCUIT AND SEMICONDUCTOR DEVICE THEREOF	9484341	2016/11/01-2035/10/21	發明	美國	DRAM 生產製程
547	STATIC RANDOM ACCESS MEMORY	9484349	2016/11/01-2035/10/28	發明	美國	DRAM 生產製程
548	METHOD OF MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR DEVICE	9490349	2016/11/08-2035/07/28	發明	美國	DRAM 生產製程
549	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	9496418	2016/11/15-2035/05/05	發明	美國	DRAM 生產製程
550	NEGATIVE REFERENCE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT	9502969	2016/11/22-2035/08/06	發明	美國	DRAM 生產製程
551	METHOD OF DETECTING PHOTOLITHOGRAPHIC	9508138	2016/11/29-2035/06/18	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	HOTSPOTS					
552	NON-VOLATILE MEMORY APPARATUS AND WRITING CIRCUIT AND METHOD FOR NON-VOLATILE MEMORY APPARATUS	9530507	2016/12/27-2035/09/09	發明	美國	DRAM 生產製程
553	SEMICONDUCTOR TRANSISTOR AND FLASH MEMORY, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9536890	2017/01/03-2035/04/17	發明	美國	DRAM 生產製程
554	VOLTAGE GENERATING CIRCUIT AND REGULATOR CIRCUIT FOR PRECISELY CONTROL PREDETERMINED HIGH VOLTAGE	9537398	2017/01/03-2035/07/14	發明	美國	DRAM 生產製程
555	MANUFACTURING METHOD OF VERTICAL CHANNEL TRANSISTOR ARRAY	9576963	2017/02/21-2031/05/28	發明	美國	DRAM 生產製程
556	INTERNAL POWER SUPPLY VOLTAGE AUXILIARY CIRCUIT, SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE	9589657	2017/03/07-2035/06/23	發明	美國	DRAM 生產製程
557	METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE	9613995	2017/04/04-2035/09/25	發明	美國	邏輯 IC
558	METHOD FOR FABRICATING NON-VOLATILE MEMORY WITH ONO STACK	9620368	2017/04/11-2035/01/22	發明	美國	DRAM 生產製程
559	IMAGE SENSOR DEVICE	9620544	2017/04/11-2035/09/07	發明	美國	邏輯 IC
560	CAPACITOR STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	9627468	2017/04/18-2035/08/21	發明	美國	DRAM 生產製程
561	SEMICONDUCTOR DEVICE CONTROL CIRCUIT AND METHOD THEREOF	9640272	2017/05/02-2035/08/06	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
562	VOLATILE SEMICONDCUTOR MEMORY DEVICE, REFRESH CONTROL CIRCUIT AND METHOD THEREOF	9653142	2017/05/16-2036/04/29	發明	美國	DRAM 生產製程
563	SEMICONDUCTOR DEVICE	9679934	2017/06/13-2035/09/25	發明	美國	邏輯 IC
564	NON-VALATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND LOCATION BASED ERASURE METHODS	9704579	2017/07/11-2036/07/26	發明	美國	DRAM 生產製程
565	DISPATCH CONTROL METHOD FOR FURNACE PROCESS	9709335	2017/07/18-2036/04/01	發明	美國	DRAM 生產製程
566	MULTILAYER CROWN-SHAPED MIM CAPACITOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	9735228	2017/08/15-2036/01/03	發明	美國	邏輯 IC
567	NON-VOLATILE MEMORY AND FABRICATING METHOD THEREOF	9780195	2017/10/03-2035/08/04	發明	美國	DRAM 生產製程
568	METHOD, IMAGE PROCESSING SYSTEM AND COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM FOR ITEM DEFECT INSPECTION	9811899	2017/11/07-2036/04/27	發明	美國	DRAM 生產製程
569	PROCESS CONTROL METHOD AND PROCESS CONTROL SYSTEM	9864363	2018/01/09-2036/07/02	發明	美國	DRAM 生產製程
570	SEMICONDUCTOR MEMORY APPARATUS	9865327	2018/01/09-2037/03/28	發明	美國	DRAM 生產製程
571	IMAGE SENSOR AND RELATED FABRICATION METHOD	9899436	2018/02/20-2036/10/26	發明	美國	邏輯 IC
572	NONPARAMETRIC METHOD FOR MEASURING CLUSTERED LEVEL OF TIME RANK IN BINARY DATA	9904660	2018/02/27-2036/11/10	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
573	SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE PROVIDED WITH DRAM CELL INCLUDING TWO TRANSISTORS AND COMMON CAPACITOR	10020311	2018/07/10-2037/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
574	VOLTAGE REGULATION DEVICE CAPABLE OF STABILIZING OUTPUT VOLTAGE	10048717	2018/08/14-2037/12/07	發明	美國	DRAM 生產製程
575	POWER CONTROL CIRCUIT AND LOGIC CIRCUIT DEVICE HAVING THE SAME	10082820	2018/09/25-2038/01/09	發明	美國	DRAM 生產製程
576	RECONFIGURING IMAGE BRIGHTNESS MODULE AND RELATED METHOD	10088753	2018/10/02-2037/08/02	發明	美國	DRAM 生產製程
577	非挥发性存储器的制造方法	387956	2008/04/02-2025/04/18	發明	中國	DRAM 生產製程
578	防止击穿的半导体元件的制造方法	390994	2008/04/16-2025/04/18	發明	中國	DRAM 生產製程
579	沟槽式栅介电层的形成方法	469584	2009/02/11-2025/04/18	發明	中國	DRAM 生產製程
580	动态随机存取存储器及其制造方法	471664	2009/02/18-2025/08/16	發明	中國	DRAM 生產製程
581	探针测量装置及系统	582094	2009/12/23-2026/01/19	發明	中國	DRAM 生產製程
582	图像传感器结构及其制造方法	582716	2009/12/23-2026/12/18	發明	中國	邏輯 IC
583	图像传感器及其制作方法	587759	2010/01/06-2026/12/19	發明	中國	邏輯 IC
584	相变存储装置及其制造方法	595042	2010/01/27-2027/05/15	發明	中國	DRAM 生產製程
585	相变化存储器及其制造方法	634309	2010/06/09-2027/09/24	發明	中國	DRAM 生產製程
586	具有电容器的半导体器件及其制造方法	650509	2010/07/21-2026/11/01	發明	中國	DRAM 生產製程
587	制作快闪存储器的方法	627788	2010/06/02-2027/09/29	發明	中國	DRAM 生產製程
588	自行对准接触窗及其制造方法	690530	2010/10/20-2027/01/30	發明	中國	DRAM 生產製程
589	图像传感器及其制作方法	692279	2010/10/27-2027/03/22	發明	中國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
590	瓶身锁定装置以及液体管理系统及其方法	7048882	2010/12/01-2027/08/06	發明	中國	DRAM 生產製程
591	偏轴光源、遮光板及以单次曝光定义不同形态图案的方法	755745	2011/04/06-2028/09/22	發明	中國	DRAM 生產製程
592	集成电路与放电电路	778187	2011/05/11-2028/02/04	發明	中國	DRAM 生產製程
593	元件的制造方法	809292	2011/07/20-2028/09/23	發明	中國	DRAM 生產製程
594	风扇模块	853693	2011/10/19-2029/02/03	發明	中國	DRAM 生產製程
595	存储器装置以及数据读取方法	882543	2011/12/21-2028/02/03	發明	中國	DRAM 生產製程
596	存储器编程方法以及数据存取方法	881115	2011/12/21-2028/02/03	發明	中國	DRAM 生產製程
597	动态随机存取存储器的冠状电容器的制作工艺及结构	884378	2011/12/21-2029/06/07	發明	中國	DRAM 生產製程
598	相变化存储装置及其制造方法	909529	2012/02/15-2028/12/26	發明	中國	DRAM 生產製程
599	相变化内存组件及其制造方法	1113013	2013/01/02-2029/03/27	發明	中國	DRAM 生產製程
600	非易失性存储器及其制造方法	102054844 B	2013/01/09-2029/11/10	發明	中國	DRAM 生產製程
601	光感测器	2732638	2017/12/08-2033/10/14	發明	中國	邏輯 IC
602	非易失性半导体存储装置	1132249	2013/02/06-2029/12/18	發明	中國	DRAM 生產製程
603	非易失性半导体存储装置用的页缓冲电路及其控制方法	1156010	2013/03/20-2029/11/06	發明	中國	DRAM 生產製程
604	微機電系統結構的製造方法	1240731	2013/07/24-2030/01/28	發明	中國	邏輯 IC
605	单次可编程只读存储器及其制造方法与操作方法	CN1240731	2013/06/12-2030/08/03	發明	中國	DRAM 生產製程
606	垂直沟道晶体管阵列及其制造方法	1278618	2013/09/25-2030/09/17	發明	中國	DRAM 生產製程
607	NAND 闪存装置的编程方法	1440777	2014/07/16-2029/04/30	發明	中國	DRAM 生產製程
608	具有垂直沟道晶体管的动态随机存取存储单元及阵列	1487741	2014/09/24-2030/12/28	發明	中國	DRAM 生產製程
609	动态随机存取存储器的电容器下电极的制造方法	1512524	2014/11/05-2030/09/14	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
610	非易失性存储器元件及其制造方法	1613665	2015/03/25-2031/04/28	發明	中國	DRAM 生產製程
611	半導體結構及其製造方法	102956560	2015/04/15-2032/02/02	發明	中國	DRAM 生產製程
612	垂直沟道晶体管阵列及其制造方法	1652580	2015/04/29-2031/04/07	發明	中國	DRAM 生產製程
613	立体垂直式存储器的制作方法	1838469	2015/11/18-2032/07/26	發明	中國	DRAM 生產製程
614	半导体线路制作工艺	1838573	2015/11/18-2032/05/11	發明	中國	DRAM 生產製程
615	半导体元件的制造方法	1953726	2016/02/17-2022/07/12	發明	中國	DRAM 生產製程
616	内部电压调整电路，内部电压调整方法以及半导体装置	2044370	2016/04/27-2033/02/05	發明	中國	DRAM 生產製程
617	一種半導體電路結構及其製程	2083999	2016/05/25-2032/05/11	發明	中國	DRAM 生產製程
618	半导体存储装置及其 ID 码及上位地址写入方法	2083219	2016/05/25-2032/08/10	發明	中國	DRAM 生產製程
619	结合红外线感测功能的多波段光感器及其制造方法	104425644 B	2016/08/17-2033/09/09	發明	中國	邏輯 IC
620	半导体结构的制造方法	103579121	2016/08/24-2032/08/02	發明	中國	DRAM 生產製程
621	非易失性半导体存储装置及其读出方法	2197062	2016/08/24-2033/01/08	發明	中國	DRAM 生產製程
622	非易失性半导体存储装置及其读出方法	2298048	2016/11/23-2033/06/07	發明	中國	DRAM 生產製程
623	电阻式存储器单元及其制作方法	2318098	2016/12/21-2032/10/18	發明	中國	DRAM 生產製程
624	非易失性半导体存储器装置及其写入方法	2320395	2016/12/28-2032/08/01	發明	中國	DRAM 生產製程
625	电平移位电路以及利用电平移位电路的半导体装置	2484258	2017/05/17-2032/11/23	發明	中國	DRAM 生產製程
626	电阻式随机存取存储器	2490440	2017/05/17-2034/03/18	發明	中國	DRAM 生產製程
627	互补金属氧化物半导体 影像感测单元及其制造方法	2546050	2017/07/07-2035/04/27	發明	中國	邏輯 IC
628	非挥发性存储器及其制作方法	2590480	2017/08/18-2033/04/16	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
629	负基准电压产生电路	2623913	2017/09/15-2035/08/27	發明	中國	DRAM 生產製程
630	非易失性半导体存储装置以及其控制方法	2667934	2017/10/24-2034/04/25	發明	中國	DRAM 生產製程
631	三维存储器的阵列结构及其制造方法	2694950	2017/11/10-2034/10/10	發明	中國	DRAM 生產製程
632	检测光刻热点的方法	2714081	2017/11/24-2035/05/14	發明	中國	邏輯 IC
633	承载治具	2751325	2017/12/22-2034/09/04	發明	中國	DRAM 生產製程
634	高压自举式栅极驱动装置	2759888	2017/12/29-2034/06/05	發明	中國	邏輯 IC
635	存储器线路结构以及其半导体线路制作工艺	2806007	2018/02/06-2033/12/06	發明	中國	DRAM 生產製程
636	工艺控制方法与工艺控制系统	2824332	2018/02/23-2034/09/02	發明	中國	DRAM 生產製程
637	负基准电压产生电路及负基准电压产生系统	2838455	2018/03/06-2035/06/11	發明	中國	DRAM 生產製程
638	存储器结构及其操作方法	2884848	2018/04/13-2034/06/05	發明	中國	DRAM 生產製程
639	晶片传送盒搬运方法、桥接储存器、以及控制装置	2884835	2018/04/13-2035/01/06	發明	中國	DRAM 生產製程
640	曝光机台的遮光装置	2991412	2018/07/06-2034/10/09	發明	中國	DRAM 生產製程
641	可进行在线叠对精度监测的测试元结构	2991269	2018/07/06-2035/02/04	發明	中國	DRAM 生產製程
642	闪存存储器的制作方法	3048395	2018/08/24-2034/11/03	發明	中國	DRAM 生產製程
643	电阻式随机存取存储器及其制造方法	3046492	2018/08/24-2034/11/13	發明	中國	DRAM 生產製程
644	半导体结构的制造方法	3053769	2018/08/31-2035/02/15	發明	中國	DRAM 生產製程
645	闪存存储器及其制造方法	3070168	2018/09/11-2034/12/18	發明	中國	DRAM 生產製程
646	非挥发性存储器及其制造方法	3080644	2018/09/21-2034/12/22	發明	中國	DRAM 生產製程
647	静态随机存取存储器与其制造方法	3080646	2018/09/21-2034/12/25	發明	中國	DRAM 生產製程
648	芯片可靠度的测试板及其测试系统	3090390	2018/09/28-2034/12/29	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
649	电阻式随机存取存储器结构及其随机存取存储器操作方法	3090384	2018/09/28-2034/12/11	發明	中國	DRAM 生產製程
650	非挥发性存储器的制造方法	3093644	2018/09/28-2035/01/22	發明	中國	DRAM 生產製程
651	止逆阀及防止气体回冲的系统	3092137	2018/09/28-2036/01/05	發明	中國	DRAM 生產製程
652	图案化方法	3125727	2018/10/26-2035/06/02	發明	中國	DRAM 生產製程
653	浮置栅极与非挥发性存储单元的制造方法	3125730	2018/10/26-2035/06/19	發明	中國	DRAM 生產製程
654	多层王冠型金属-绝缘体-金属电容器结构及其制作方法	3123040	2018/10/26-2035/10/13	發明	中國	邏輯 IC
655	NOR 型闪存存储器结构及其制造方法	3244255	2019/02/05-2034/04/15	發明	中國	DRAM 生產製程
656	炉管制作工艺的派工控制方法	3246586	2019/02/05-2034/08/26	發明	中國	DRAM 生產製程
657	电阻式随机存取存储器及其制造方法	3243948	2019/02/05-2035/02/09	發明	中國	DRAM 生產製程
658	电阻式随机存取存储器结构	3243997	2019/02/05-2035/07/21	發明	中國	DRAM 生產製程
659	半导体装置的制作方法	3242760	2019/02/05-2035/03/31	發明	中國	DRAM 生產製程
660	双位闪存存储器结构及其制造方法	3250304	2019/02/12-2035/02/15	發明	中國	DRAM 生產製程
661	半导体晶片、半导体芯片以及半导体装置及其制造方法	3283751	2019/03/08-2035/01/26	發明	中國	DRAM 生產製程
662	金属氧化物金属电容器电路及其半导体装置	3280736	2019/03/08-2036/01/07	發明	中國	DRAM 生產製程
663	PMI-半导体记忆装置及半导体集成电路装置	3282139	2019/03/08-2035/08/20	發明	中國	DRAM 生產製程
664	半导体存储器装置	3282788	2019/03/08-2035/12/02	發明	中國	DRAM 生產製程
665	动态存储器测试装置及其测试方法	3335359	2019/04/16-2035/01/08	發明	中國	DRAM 生產製程
666	非挥发性存储器及其制造方法	3338848	2019/04/16-2035/01/12	發明	中國	DRAM 生產製程
667	半导体晶体管与闪存存储器及其制造方法	3335880	2019/04/16-2035/05/18	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
668	半导体元件的制作方法	3335887	2019/04/16-2035/06/01	發明	中國	DRAM 生產製程
669	半導體元件及其製造方法	3335587	2019/04/16-2035/08/05	發明	中國	邏輯 IC
670	电容器结构及其制造方法	3335890	2019/04/16-2035/06/12	發明	中國	DRAM 生產製程
671	襯墊應力層	註		發明	中國	NA
672	化学機械研磨装置用ダミー処理方法及び研磨パッドコンディショニング方法	4125278	2008/05/16-2024/10/08	發明	日本	DRAM 生產製程
673	ＥＰＲＯＭデバイスおよびその製造方法ならびにそのプログラミング方法と読み取り方法	4143421	2008/06/20-2023/01/08	發明	日本	DRAM 生產製程
674	半導体製造装置の早期警報管理方法及びシステム	4177780	2008/08/29-2024/03/31	發明	日本	DRAM 生產製程
675	濾過装置	4195422	2008/10/03-2024/07/06	發明	日本	DRAM 生產製程
676	プローブ装置およびシステム	4422127	2009/12/11-2026/08/10	發明	日本	DRAM 生產製程
677	不揮発性半導体記憶装置とその書き込み方法	4510072	2010/05/14-2027/12/20	發明	日本	DRAM 生產製程
678	液体供給を管理するためのタンクロック装置・システムとそれを使用する方法	4702394	2011/03/18-2028/05/16	發明	日本	DRAM 生產製程
679	不揮発性半導体記憶装置とその自己テスト方法	4750813	2011/05/27-2028/03/07	發明	日本	DRAM 生產製程
680	昇圧回路の制御回路	4791560	2011/07/29-2029/04/13	發明	日本	DRAM 生產製程
681	イメージセンサー及びその製作方法	4961590	2012/04/06-2027/04/13	發明	日本	邏輯 IC
682	不揮発性半導体記憶装置とその読み出し方法	5081755	2012/09/07-2028/07/18	發明	日本	DRAM 生產製程
683	不揮発性半導体記憶装置のためのページバッファ回路とその制御方法	5086972	2012/09/14-2028/11/06	發明	日本	DRAM 生產製程
684	不揮発性半導体記憶装置	5175561	2013/01/11-2028/01/28	發明	日本	DRAM 生產製程
685	不揮発性半導体記憶装置	5231972	2013/03/29-2028/12/18	發明	日本	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
686	不揮発性半導体記憶装置とその制御方法、データ圧縮回路、データ展開回路、並びにデータ圧縮展開回路	5261059	2013/05/02-2028/07/31	發明	日本	DRAM 生產製程
687	不揮発性半導体記憶装置とそのフェイルビット数計数方法	5284737	2013/06/07-2028/09/19	發明	日本	DRAM 生產製程
688	NAND 型フラッシュメモリとその消去方法	5284909	2013/06/07-2029/08/26	發明	日本	DRAM 生產製程
689	不揮発性半導体記憶装置とその書き込み方法	5292052	2013/06/14-2028/10/21	發明	日本	DRAM 生產製程
690	半導体記憶装置並びにそのＩＤコード及び上位アドレスの書き込み方法	5337273	2013/08/09-2032/04/18	發明	日本	DRAM 生產製程
691	不揮発性半導体記憶装置とその読み出し方法	5385435	2013/10/11-2032/07/18	發明	日本	DRAM 生產製程
692	レベルシフト回路及びそれを用いた半導体デバイス	5395203	2013/10/25-2032/03/23	發明	日本	DRAM 生產製程
693	内部電圧トリミング回路及び方法、並びに半導体回路装置	5518134	2014/04/11-2032/07/02	發明	日本	DRAM 生產製程
694	不揮発性半導体記憶装置とその読み出し方法	5586666	2014/08/01-2032/08/01	發明	日本	DRAM 生產製程
695	不揮発性半導体記憶装置とその制御方法	5678151	2015/01/09-2033/09/18	發明	日本	DRAM 生產製程
696	不揮発性メモリの WL 電圧とタイミング制御方法	5745136	2015/05/15-2034/05/09	發明	日本	DRAM 生產製程
697	不揮発性半導体記憶装置とその書き込み方法	5784788	2015/07/31-2032/01/06	發明	日本	DRAM 生產製程
698	負基準電圧発生回路及び負基準電圧発生システム	5882397	2016/02/12-2034/06/05	發明	日本	DRAM 生產製程
699	不揮発性記憶装置のための書き込み回路及び方法、並びに不揮発性記憶装置	5909294	2016/04/01-2035/03/11	發明	日本	DRAM 生產製程
700	スイッチドキャパシタ回路による負電圧の基準電圧回路,	5911614	2016/04/08-2035/01/19	發明	日本	DRAM 生產製程
701	半導体装置の制御回路及び方法、並びに半導体装置	5931236	2016/05/13-2035/02/05	發明	日本	DRAM 生產製程
702	半導体記憶装置	5941577	2016/05/27-2035/05/11	發明	日本	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
703	半導体ウエハ、半導体チップ及び半導体装置とそれらの製造方法	5976055	2016/07/29-2034/08/21	發明	日本	DRAM 生產製程
704	半導体デバイスの降圧内部電源回路	5976077	2016/07/29-2034/11/14	發明	日本	DRAM 生產製程
705	承載治具	5986170	2016/08/12-2034/11/13	發明	日本	DRAM 生產製程
706	電圧発生回路、レギュレータ回路、半導体記憶装置及び半導体装置	5982510	2016/08/05-2035/02/09	發明	日本	DRAM 生產製程
707	負基準電壓發生回路	6017593	2016/10/07-2035/01/13	發明	日本	DRAM 生產製程
708	内部電源電圧補助回路、半導体記憶装置及び半導体装置	6050804	2016/12/02-2034/11/28	發明	日本	DRAM 生產製程
709	ラッチ回路及び半導体記憶装置	6069544	2017/01/06-2036/01/19	發明	日本	DRAM 生產製程
710	揮発性半導体記憶装置のリフレッシュ制御回路及び方法、並びに揮発性半導体記憶装置	6084318	2017/02/03-2036/02/22	發明	日本	DRAM 生產製程
711	半導体記憶装置及び半導体集積回路装置	6097775	2017/02/24-2035/02/16	發明	日本	DRAM 生產製程
712	チップ内部波形のモニター方法及び回路	6097797	2017/02/24-2035/08/07	發明	日本	DRAM 生產製程
713	不揮発性記憶装置のためのセンス回路及び不揮発性記憶装置	6114796	2017/03/24-2035/10/05	發明	日本	DRAM 生產製程
714	フラッシュメモリ構造、及びフラッシュメモリ構造を製造する方法	6131290	2017/04/21-2035/05/19	發明	日本	DRAM 生產製程
715	半導体記憶装置とそのアドレス制御方法	6131357	2017/04/21-2036/03/18	發明	日本	DRAM 生產製程
716	炉内プロセスのディスパッチ制御方法	6133911	2017/04/28-2035/01/22	發明	日本	DRAM 生產製程
717	トランジスタテスト回路及び方法、半導体記憶装置、並びに半導体装置	6132860	2017/04/28-2035/01/22	發明	日本	DRAM 生產製程
718	半導体記憶装置	6166810	2017/06/30-2036/03/08	發明	日本	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
719	スイッチドキャパシタ回路及びＡＤ変換装置	6215398	2017/09/29-2036/06/22	發明	日本	DRAM 生產製程
720	半導體記憶裝置	6251793	2017/12/01-2036/10/28	發明	日本	DRAM 生產製程
721	半導体記憶装置	6259889	2017/12/15-2036/11/04	發明	日本	DRAM 生產製程
722	ＳＲＡＭ装置のための冗長回路、ＳＲＡＭ装置、及び半導体装置	6360610	2018/06/29-2037/11/22	發明	日本	DRAM 生產製程
723	電源制御回路及び電源制御回路を備えた論理回路装置	6389937	2018/08/24-2037/08/29	發明	日本	DRAM 生產製程
724	NAND フラッシュメモリデバイスのプログラミング方法	4750906	2011/05/27-2029/04/30	發明	日本	DRAM 生產製程
725	法拉第杯	M426862	2012/4/11-2021/10/26	新型	臺灣	DRAM 生產製程
726	離子收斂器及離子植佈機	M457284	2013/7/11-2023/01/28	新型	臺灣	DRAM 生產製程
727	法拉第杯	2330907	2012/8/1-2021/11/17	新型	中國	DRAM 生產製程
728	離子收斂器及離子植布機	3087125	2013/8/7-2023/02/07	新型	中國	DRAM 生產製程
729	靜電放電保護元件	I661530	2019/06/01-2038/02/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
730	半導體裝置及其製造方法	I662687	2019/06/11-2037/04/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
731	光管結構、其製造方法及影像感測元件	I662319	2019/06/11-2037/09/26	發明	臺灣	邏輯 IC
732	用於拼接式微影製程的光罩、半色調光罩及其製作方法	I669566	2019/08/21-2038/01/17	發明	臺灣	邏輯 IC
733	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I669805	2019/08/21-2038/01/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
734	具有類光導管結構之影像感測器	I669811	2019/08/21-2038/01/31	發明	臺灣	邏輯 IC
735	開孔及其形成方法	I675399	2019/10/21-2037/08/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
736	電源控制電路以及具備電源控制電路的邏輯電路裝置	I675291	2019/10/21-2038/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
737	影像感測器及其製造方法	I675467	2019/10/21-2038/08/28	發明	臺灣	邏輯 IC
738	金屬-氧化物-金屬電容結構	I675478	2019/10/21-2038/10/29	發明	臺灣	邏輯 IC
739	記憶體結構及其製造方法	I675460	2019/10/21-2038/12/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
740	記憶體元件及其製造方法	I675453	2019/10/21-2039/02/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
741	記憶體結構及其製造方法	I675457	2019/10/21-2038/12/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
742	用於全局式快門的互補式金屬氧化物半導體影像感測器	I679755	2019/12/11-2038/10/22	發明	臺灣	邏輯 IC
743	記憶體元件及其製造方法	I679752	2019/12/11-2038/12/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
744	半導體元件的製造方法	I679690	2019/12/11-2038/10/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
745	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	I679757	2019/12/11-2039/02/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
746	階梯式元件及其製造方法	I679768	2019/12/11-2039/01/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
747	研磨墊	I679083	2019/12/11-2039/01/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
748	被動元件-MCP0046-電容集成結構及其電容	I679662	2019/12/11-2039/07/31	發明	臺灣	邏輯 IC
749	半導體記憶裝置	I645405	2018/12/21-2037/03/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
750	CMOS 影像感測器的深溝渠隔離結構及其製造方法	I645554	2018/12/21-2037/10/05	發明	臺灣	邏輯 IC
751	溝渠式隔離結構的製造方法及高壓半導體元件	I685919	2020/02/21-2039/01/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
752	影像感測器及其製造方法	I685959	2020/02/21-2039/01/06	發明	臺灣	邏輯 IC
753	光二極體結構其製造方法	I685983	2020/02/21-2038/12/03	發明	臺灣	邏輯 IC
754	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I685951	2020/02/21-2038/10/07	發明	臺灣	DRAM 生產製程
755	影像感測器及其製造方法	I685958	2020/02/21-2038/12/12	發明	臺灣	邏輯 IC
756	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I685954	2020/02/21-2038/12/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
757	半導體元件及其製造方法	I685978	2020/02/21-2039/01/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
758	記憶體結構及其製造方法	I685948	2020/02/21-2039/01/31	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
						生產製程
759	工作溶液的更新方法	I685879	2020/02/21-2039/06/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
760	具有傾斜面之閘介電層及其半導體結構的製造方法	I685918	2020/02/21-2038/12/13	發明	臺灣	邏輯 IC
761	非揮發性記憶體結構	I685949	2020/02/21-2039/05/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
762	記憶體結構及其製造方法	I691098	2020/04/11-2038/11/18	發明	臺灣	邏輯 IC
763	半導體元件及其製造方法	I691096	2020/04/11-2039/01/27	發明	臺灣	邏輯 IC
764	補償非易失性記憶元件在編程時電荷流失與源極線偏置的方法	I690930	2020/04/11-2039/01/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
765	半導體製程	I691000	2020/04/11-2038/11/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
766	記憶體結構的製造方法	I691024	2020/04/11-2039/02/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
767	光罩的設計方法與半導體微影製程	I690768	2020/04/11-2039/01/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
768	基於記憶體處理器的多處理架構及其操作方法	I690848	2020/04/11-2039/03/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
769	記憶體結構及其製造方法	I691052	2020/04/11-2039/05/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
770	電流電壓轉換電路、基準電壓產生電路及非揮發性半導體存儲裝置	I690934	2020/04/11-2039/05/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
771	記憶體結構	I691051	2020/04/11-2039/05/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
772	電容單元及其製造方法	I691092	2020/04/11-2038/11/04	發明	臺灣	邏輯 IC
773	記憶體結構及其製造方法	I696266	2020/06/11-2038/12/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
774	頁緩衝電路與非揮發性儲存裝置	I696182	2020/06/11-2039/07/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
775	記憶體結構	I696285	2020/06/11-2039/05/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
776	記憶體結構及其製造方法	I696263	2020/06/11-2039/05/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
777	記憶體結構	I696247	2020/06/11-2039/01/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
778	靜態隨機存取記憶體及其製作方法	I696268	2020/06/11-2039/01/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
779	記憶體結構及其製造方法	I696272	2020/06/11-2038/11/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
780	用於帶電粒子束檢測之檢測結構及用其檢測缺陷的檢測方法	I696207	2020/06/11-2039/03/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
781	貨物搬運系統及貨物搬運方法	I695805	2020/06/11-2039/08/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
782	數位類比轉換電路、不良位元數檢測電路及非揮發性半導體存儲裝置	I696353	2020/06/11-2039/05/02	發明	臺灣	DRAM 生產製程
783	記憶體結構及其製造方法	I696270	2020/06/11-2039/04/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
784	具有輔助閘的快閃記憶體暨其製作方法	I696273	2020/06/11-2039/05/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
785	研磨後清潔裝置	I695741	2020/06/11-2039/09/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
786	遮蔽閘金氧半場效電晶體及其製造方法	I696288	2020/06/11-2039/07/15	發明	臺灣	邏輯 IC
787	用於雙電晶體靜態隨機存取記憶體的位元線結構	I696177	2020/06/11-2039/10/01	發明	臺灣	DRAM 生產製程
788	影像感測器及其製造方法	I701823	2020/08/11-2038/09/30	發明	臺灣	邏輯 IC
789	記憶體結構及其製造方法	I701804	2020/08/11-2039/01/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
790	晶圓夾盤裝置、晶圓形變量的量測方法及半導體製造流程	I701751	2020/08/11-2039/03/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
791	半導體結構及其製造方法	I701789	2020/08/11-2039/07/22	發明	臺灣	邏輯 IC
792	非揮發性記憶體結構	I701811	2020/08/11-2039/05/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
793	缺陷分析方法與記憶體晶片	I701429	2020/08/11-2039/09/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
794	標記的製造方法	I701797	2020/08/11-2039/07/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
795	影像感測器及其製造方法	I701842	2020/08/11-2039/08/04	發明	臺灣	邏輯 IC
796	內連線結構的製造方法	I701768	2020/08/11-2039/08/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
797	記憶體、記憶體晶片以及記憶體資料存取方法	I716299	2021/01/11-2040/03/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
798	記憶體元件及其製造方法	I720432	2021/03/01-2039/03/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
799	多層電容元件以及多層電容元件的設計方法	I720886	2021/03/01-2040/05/07	發明	臺灣	邏輯 IC
800	半導體裝置及其製造方法	I725891	2021/04/21-2040/07/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
801	半導體離子植入機的離子源頭結構	I725384	2021/04/21-2039/02/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
802	半導體封裝	I725635	2021/04/21-2039/11/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
803	失效位元數目計數電路及非揮發性半導體儲存裝置	I725799	2021/04/21-2040/03/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
804	具有表面微柱體結構的固態影像感測器暨其製作方法	I725765	2021/04/21-2040/03/09	發明	臺灣	邏輯 IC
805	半導體結構及其製造方法	I725783	2021/04/21-2040/03/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
806	影像感測模組	I725827	2021/04/21-2040/04/23	發明	臺灣	邏輯 IC
807	記憶體結構及其製造方法	I725767	2021/04/21-2040/03/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
808	電容器及其製造方法	I725769	2021/04/21-2040/03/12	發明	臺灣	邏輯 IC
809	鋁層的蝕刻後保護方法	I730419	2021/06/11-2039/09/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
810	插塞偏移的監控測試結構	I730385	2021/06/11-2039/08/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
811	絕緣閘極場效雙極性電晶體及其製造方法	I730732	2021/06/11-2040/04/21	發明	臺灣	邏輯 IC
812	絕緣閘雙極電晶體結構及其製造方法	I730814	2021/06/11-2040/06/15	發明	臺灣	邏輯 IC
813	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	I730736	2021/06/11-2040/04/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
814	記憶體結構的製造方法	I730718	2021/06/11-2040/04/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
815	記憶體元件及其製造方法	I730677	2021/06/11-2040/03/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
816	半導體元件的製造方法	I730769	2021/06/11-2040/05/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
817	互補式金氧半導體影像感測器	I730868	2021/06/11-2040/08/05	發明	臺灣	邏輯 IC
818	半導體結構以及積體電路及半	I730725	2021/06/11-2040/04/14	發明	臺灣	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	導體結構					生產製程
819	影像感測器的製造方法及對準標記結構	I730799	2021/06/11-2040/06/03	發明	臺灣	邏輯 IC
820	對準標記結構及影像感測器的製造方法	I730798	2021/06/11-2040/06/03	發明	臺灣	邏輯 IC
821	線路末端結構及其形成方法	I730869	2021/06/11-2040/08/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
822	多重圖案化方法	I730821	2021/06/11-2040/06/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
823	相位轉移光罩的製造方法	I707195	2020/10/11-2040/02/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
824	非揮發性半導體記憶體裝置的抹除控制電路、方法以及非揮發性半導體記憶體裝置	I707348	2020/10/11-2039/10/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
825	半導體結構的製造方法	I707385	2020/10/11-2039/10/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
826	資料寫入方法和儲存控制器	I707362	2020/10/11-2039/08/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
827	電路架構	I707438	2020/10/11-2039/07/18	發明	臺灣	邏輯 IC
828	電源開關控制電路及其控制方法	I707526	2020/10/11-2039/07/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
829	NAND 快閃記憶體的寫入方法	I707343	2020/10/11-2039/07/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
830	影像感測器及其製造方法	I707481	2020/10/11-2039/03/07	發明	臺灣	邏輯 IC
831	淺溝渠隔離結構中的針狀缺陷的監測方法	I714494	2020/12/21-2040/04/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
832	晶圓載具運輸系統	I714472	2020/12/21-2040/03/11	發明	臺灣	DRAM 生產製程
833	微透鏡結構及其製造方法	I714445	2020/12/21-2040/01/21	發明	臺灣	邏輯 IC
834	具有隱藏的識別碼的半導體堆疊結構	I714419	2020/12/21-2040/01/05	發明	臺灣	DRAM 生產製程
835	晶圓圖的辨識方法與電腦可讀取記錄媒體	I714371	2020/12/21-2039/11/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
836	影像感測器	I714266	2020/12/21-2039/09/17	發明	臺灣	邏輯 IC
837	可執行人工智慧運算的記憶體晶片及其操作方法	I714003	2020/12/21-2039/02/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
838	記憶體結構及其製造方法	I713980	2020/12/21-2039/01/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
839	半導體元件及其製造方法	I713978	2020/12/21-2039/01/18	發明	臺灣	DRAM 生產製程
840	記憶體結構	I713973	2020/12/21-2039/01/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
841	製程控制系統與方法	I713919	2020/12/21-2038/10/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
842	快閃記憶體裝置及其程式化方法	I713860	2020/12/21-2038/06/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
843	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE AND METHOD FOR PREVENTING NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE FROM GENERATING PROGRAM DISTURBANCE	10290644	2019/05/14-2037/06/14	發明	美國	DRAM 生產製程
844	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND ERROR COMPENSATION METHOD FOR VERIFYING THE SAME	10290363	2019/05/14-2038/02/26	發明	美國	DRAM 生產製程
845	ELECTROSTATIC DISCHARGE PROTECTION DEVICE	10361187	2019/07/23-2038/05/10	發明	美國	DRAM 生產製程
846	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10483271	2019/11/19-2038/03/05	發明	美國	DRAM 生產製程
847	STATIC RANDOM-ACCESS MEMORY DEVICE, REDUNDANT CIRCUIT THEREOF, AND SEMICONDUCTOR DEVICE	10497431	2019/12/03-2038/04/09	發明	美國	DRAM 生產製程
848	INTEGRATED CIRCUIT STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10504914	2019/12/10-2038/05/28	發明	美國	DRAM 生產製程
849	METHOD FOR MANUFACTURING MULTILAYER CROWN-	10121848	2018/11/06-2036/02/26	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	SHAPED MIM CAPACITOR					
850	MANUFACTURING METHOD OF NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	10600798	2020/03/24-2038/03/05	發明	美國	DRAM 生產製程
851	IMAGE SENSOR AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	10629644	2020/04/21-2038/12/22	發明	美國	邏輯 IC
852	ION SOURCE HEAD STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR ION IMPLANTER	10658149	2020/05/19-2039/04/03	發明	美國	DRAM 生產製程
853	METAL-OXIDE-METAL CAPACITOR STRUCTURE	10672863	2020/06/02-2039/04/02	發明	美國	邏輯 IC
854	PAGE BUFFER CIRCUIT AND NONVOLATILE STORAGE DEVICE	10714190	2020/07/14-2039/02/20	發明	美國	DRAM 生產製程
855	DIGITAL TO ANALOG CONVERTOR, FAILURE BIT NUMBER DETECTOR AND NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE	10720932	2020/07/21-2039/07/26	發明	美國	DRAM 生產製程
856	FLASH MEMORY WITH ASSISTANT GATE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	10892341	2021/01/12-2039/07/23	發明	美國	DRAM 生產製程
857	MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10896910	2021/01/19-2039/05/24	發明	美國	DRAM 生產製程
858	TRENCH TRANSISTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10903203	2021/01/26-2038/11/15	發明	美國	DRAM 生產製程
859	CIRCUIT STRUCTURE	10910368	2021/02/02-2039/09/19	發明	美國	邏輯 IC
860	IMAGE SENSOR AND MANUFACTURING METHOD THEREFORE	10937819	2021/03/02-2038/11/08	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
861	MEMORY WITH PROCESSING IN MEMORY ARCHITECTURE AND OPERATING METHOD THEREOF	10990524	2021/04/27-2039/09/10	發明	美國	DRAM 生產製程
862	FAIL BIT NUMBER COUNTING CIRCUIT AND NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR STORAGE DEVICE	11004522	2021/05/11-2040/02/21	發明	美國	DRAM 生產製程
863	RETARGETING METHOD FOR OPTICAL PROXIMITY CORRECTION	10983429	2021/04/20-2040/08/18	發明	美國	DRAM 生產製程
864	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	10971519	2021/04/06-2039/07/10	發明	美國	DRAM 生產製程
865	MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	10971501	2021/04/06-2039/07/09	發明	美國	DRAM 生產製程
866	静态随机存取存储器	3417914	2019/06/14-2035/12/09	發明	中國	DRAM 生產製程
867	半导体记忆装置	3435408	2019/06/28-2035/08/04	發明	中國	DRAM 生產製程
868	非易失性半导体存储装置与写入方法	3444015	2019/07/05-2035/05/04	發明	中國	DRAM 生產製程
869	半导体元件及其制作方法	3446009	2019/07/09-2035/01/08	發明	中國	DRAM 生產製程
870	电阻式随机存取存储器及其制造方法	3446015	2019/07/09-2035/02/15	發明	中國	DRAM 生產製程
871	非挥发性记忆体及其制造方法	3446020	2019/07/09-2035/03/11	發明	中國	DRAM 生產製程
872	非易失性存储装置与用于其的写入电路及方法	3446696	2019/07/09-2035/09/28	發明	中國	DRAM 生產製程
873	影像感应器	3448726	2019/07/09-2035/04/24	發明	中國	邏輯 IC
874	影像感应器	3449006	2019/07/09-2035/04/27	發明	中國	邏輯 IC
875	闪存装置及其编程操作的初始化方法	3447228	2019/07/09-2035/07/21	發明	中國	DRAM 生產製程
876	曝光机台对准光源装置内的模块作动监控方法及监控系统	3455179	2019/07/16-2035/01/16	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
877	负基准电压产生电路及负基准电压产生系统	3555605	2019/10/11-2035/01/19	發明	中國	DRAM 生產製程
878	非挥发性记忆体的制造方法	3551951	2019/10/11-2034/12/30	發明	中國	DRAM 生產製程
879	内部电源电压辅助电路、半导体存储装置及半导体装置	3552341	2019/10/11-2035/06/26	發明	中國	DRAM 生產製程
880	静态随机存取存储器及其制造方法	3554204	2019/10/11-2035/10/28	發明	中國	DRAM 生產製程
881	影像感测器及其制作方法	3553861	2019/10/11-2035/06/08	發明	中國	邏輯 IC
882	用于非易失性存储装置的感测电路以及非易失性存储装置	3551973	2019/10/11-2036/01/19	發明	中國	DRAM 生產製程
883	晶圆级动态预烧测试方法	3555654	2019/10/11-2035/09/22	發明	中國	DRAM 生產製程
884	半导体元件及其制作方法	3551969	2019/10/11-2036/01/07	發明	中國	DRAM 生產製程
885	内部电源电压产生电路、半导体存储装置及半导体装置	3595786	2019/11/12-2035/06/10	發明	中國	DRAM 生產製程
886	电晶管测试电路及方法、半导体记忆装置以及半导体装置	3592909	2019/11/12-2035/08/21	發明	中國	DRAM 生產製程
887	电压产生电路及调节器电路	3591620	2019/11/12-2035/08/25	發明	中國	DRAM 生產製程
888	影像感测器	3594519	2019/11/12-2035/08/20	發明	中國	邏輯 IC
889	半导体元件及其制造方法	3592325	2019/11/12-2035/11/02	發明	中國	邏輯 IC
890	半導體裝置、測試裝置及測試系統	3592960	2019/11/12-2035/12/09	發明	中國	DRAM 生產製程
891	半导体装置的控制电路及其方法	3649549	2019/12/31-2035/10/22	發明	中國	DRAM 生產製程
892	闪存存储器栅极结构及其制作方法	3160475	2020/01/01-2034/09/23	發明	中國	DRAM 生產製程
893	电阻式随机存取存储器及其制造方法	3130733	2018/11/02-2034/09/30	發明	中國	DRAM 生產製程
894	非挥发性存储器	3174003	2018/12/07-2035/01/22	發明	中國	DRAM 生產製程
895	自动监控膜厚均匀性的方法	3159745	2018/11/23-2035/07/07	發明	中國	DRAM 生產製程
896	化学机械研磨装置与方法	3182628	2018/12/14-2035/09/11	發明	中國	DRAM 生產製程
897	半导体元件及其制造方法	3653506	2020/01/03-2036/01/06	發明	中國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
898	物品缺陷检测方法、图像处理系统与计算机可读记录介质	3680466	2020/02/04-2036/02/17	發明	中國	DRAM 生產製程
899	提升圖案精密度的方法	3684745	2020/02/07-2035/03/30	發明	中國	DRAM 生產製程
900	闪存装置及数据擦除方法	3681227	2020/02/07-2035/07/17	發明	中國	DRAM 生產製程
901	横向扩散金属氧化半导体元件及其制造方法	3684544	2020/02/07-2036/02/04	發明	中國	邏輯 IC
902	影像感测器及其制作方法	3684040	2020/02/07-2036/10/28	發明	中國	邏輯 IC
903	影像感测器及其制作方法	3764788	2020/04/21-2036/09/12	發明	中國	邏輯 IC
904	半导体存储器装置及其地址控制方法	3829982	2020/04/21-2036/09/13	發明	中國	DRAM 生產製程
905	半导体存储器装置	3829280	2020/06/09-2036/10/17	發明	中國	DRAM 生產製程
906	半导体存储器装置	3829677	2020/06/09-2036/06/14	發明	中國	DRAM 生產製程
907	非挥发性存储器结构及防止其产生编程干扰的方法	3924337	2020/06/09-2037/04/28	發明	中國	DRAM 生產製程
908	鎖存電路以及半導體記憶體裝置	3918596	2020/08/04-2036/09/19	發明	中國	DRAM 生產製程
909	电容器结构及其制造方法	3918725	2020/08/04-2036/07/19	發明	中國	DRAM 生產製程
910	半导体存储装置	3919369	2020/08/04-2037/07/24	發明	中國	DRAM 生產製程
911	影像亮度重配模塊及影像亮度重配方法	3923153	2020/08/04-2037/06/02	發明	中國	DRAM 生產製程
912	稳压输出装置	3918741	2020/08/04-2037/09/04	發明	中國	DRAM 生產製程
913	半導體元件	4010632	2020/09/29-2036/09/12	發明	中國	邏輯 IC
914	垂直式记忆体及其制作方法	4008547	2020/09/29-2037/06/21	發明	中國	DRAM 生產製程
915	集成电路芯片及其检查方法	4008937	2020/09/29-2037/07/21	發明	中國	DRAM 生產製程
916	半导体装置及其制造方法	4082663	2020/11/10-2037/04/27	發明	中國	DRAM 生產製程
917	非易失性半导体存储设备及其擦除方法	4088488	2020/11/10-2036/09/22	發明	中國	DRAM 生產製程
918	静态随机存取存储器装置、其	4089004	2020/11/10-2038/05/22	發明	中國	DRAM

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
	冗余电路及半导体装置					生產製程
919	静电放电保护元件	4155515	2020/12/15-2038/03/06	發明	中國	DRAM 生產製程
920	结构上的光致抗蚀剂图案制作工艺	4151587	2020/12/16-2036/08/15	發明	中國	DRAM 生產製程
921	快闪存储器装置及其更新方法	4155938	2020/12/18-2037/04/20	發明	中國	DRAM 生產製程
922	自刷新控制装置以及易失性半导体存储器装置	4200382	2021/01/12-2036/09/08	發明	中國	DRAM 生產製程
923	存储器装置	4199389	2021/01/12-2036/12/23	發明	中國	DRAM 生產製程
924	非易失性存储器装置及对其验证的错误补偿方法	4206085	2021/01/15-2037/11/09	發明	中國	DRAM 生產製程
925	揮發性半導體記憶裝置、其再新控制電路及方法	4207583	2021/01/15-2036/06/07	發明	中國	DRAM 生產製程
926	非易失性存储器及其存取方法	4204972	2021/01/15-2037/03/17	發明	中國	DRAM 生產製程
927	图像传感器及其制作方法	4208354	2021/01/15-2037/03/17	發明	中國	邏輯 IC
928	CMOS 影像感测器的深沟渠隔离结构及其制造方法	4295463	2021/03/12-2037/10/19	發明	中國	邏輯 IC
929	非揮發性記憶體結構及其製造方法	4407054	2021/05/07-2038/01/12	發明	中國	DRAM 生產製程
930	光管结构、其制造方法及影像感测元件	4479609	2021/06/11-2037/10/12	發明	中國	邏輯 IC
931	电源开关控制电路及其控制方法	4503899	2021/06/22-2039/08/15	發明	中國	DRAM 生產製程
932	不揮発性メモリ構造およびその製造方法	6634480	2019/12/20-2038/07/10	發明	日本	DRAM 生產製程
933	パワースイッチ制御回路とその制御方法	6666985	2020/02/26-2038/11/16	發明	日本	DRAM 生產製程
934	ページバッファ回路及び不揮発性記憶装置	6677786	2020/03/17-2038/11/20	發明	日本	DRAM 生產製程
935	ＤＡ変換回路、不良ビット数検出回路及び不揮発性半導体記憶装置	6694090	2020/04/20-2029/03/01	發明	日本	DRAM 生產製程
936	不揮発性半導体記憶装置の消去制御回路及び方法、並びに不揮発性半導体記憶装置	6741811	2020/07/29-2039/03/07	發明	日本	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
937	フェイルビット数計数回路及び不揮発性半導体記憶装置	6757447	2020/09/01-2039/06/12	發明	日本	DRAM 生產製程
938	メモリプロセッサを用いた多重処理アーキテクチャ及びその動作方法	6882398	2021/05/10-2039/09/13	發明	日本	DRAM 生產製程
939	電流電圧変換回路、基準電圧発生回路及び不揮発性半導体記憶装置	6887457	2021/05/20-2039/03/01	發明	日本	DRAM 生產製程
940	光管结构、其制造方法及影像感测元件	4479609	2021/06/11-2037/10/11	發明	中國	邏輯 IC
941	电源开关控制电路及其控制方法	4503899	2021/06/22-2039/08/14	發明	中國	邏輯 IC
942	人工知能動作を実行できるメモリチップおよびその方法	6912535	2021/07/12-2039/09/20	發明	日本	邏輯 IC
943	INSULATED GATE FIELD EFFECT BIPOLAR TRANSISTOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	11063141	2021/07/13-2040/05/26	發明	美國	邏輯 IC
944	MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	11063156	2021/07/13-2040/04/27	發明	美國	邏輯 IC
945	MEMORY STRUCTURE	11069715	2021/07/20-2039/03/11	發明	美國	DRAM 生產製程
946	光掩膜及其制造方法以及曝光方法	4566525	2021/07/23-2037/03/05	發明	中國	邏輯 IC
947	ERASE CONTROL CIRCUIT AND METHOD OF NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE, AND NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE	11074979	2021/07/27-2039/09/18	發明	美國	DRAM 生產製程
948	集成电路结构及其制造方法	4589793	2021/08/03-2038/03/12	發明	中國	DRAM 生產製程
949	半导体元件及其制造方法	4610438	2021/08/10-2037/06/07	發明	中國	邏輯 IC
950	Semiconductor package	11086360	2021/08/10-2040/02/20	發明	美國	邏輯 IC

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
951	MEMORY, MEMORY CHIP AND MEMORY DATA ACCESS METHOD	11094368	2021/08/17-2040/02/03	發明	美國	邏輯 IC
952	Partial writing method of dram memoryl device to reduce power consumption associated with large voltage swing of internal input/output lines	11094372	2021/08/17-2040/05/07	發明	美國	邏輯 IC
953	半導體元件的製造方法	I736820	2021/08/21-2038/12/26	發明	臺灣	邏輯 IC
954	膜厚量測系統及膜厚量測方法	I736940	2021/08/21-2039/07/18	發明	臺灣	邏輯 IC
955	記憶體結構及其製造方法	I736947	2021/08/21-2039/08/04	發明	臺灣	DRAM 生產製程
956	半導體結構及其製造方法	I737258	2021/08/21-2040/04/12	發明	臺灣	邏輯 IC
957	半導體裝置	I737218	2021/08/21-2040/03/16	發明	臺灣	邏輯 IC
958	溝渠式電晶體結構及其製造方法	I736803	2021/08/21-2038/10/23	發明	臺灣	邏輯 IC
959	半導體元件的製造方法	I737342	2021/08/21-2040/06/09	發明	臺灣	邏輯 IC
960	半導體結構及其製造方法	I737087	2021/08/21-2039/12/18	發明	臺灣	邏輯 IC
961	缺陷辨識方法以及影像分析系統	I737375	2021/08/21-2040/06/30	發明	臺灣	邏輯 IC
962	氣體噴灑裝置、半導體基板處理設備及其操作方法	I737250	2021/08/21-2040/04/05	發明	臺灣	邏輯 IC
963	非揮發性記憶體結構	I737374	2021/08/21-2040/06/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
964	半導體元件及其製造方法	I737282	2021/08/21-2040/04/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
965	電晶體結構及其製造方法	I737417	2021/08/21-2040/07/21	發明	臺灣	邏輯 IC
966	半導體結構及其製作方法	I737377	2021/08/21-2040/06/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
967	晶圓盒搬運夾具	I737508	2021/08/21-2040/09/29	發明	臺灣	邏輯 IC
968	半導體裝置及其製造方法	I737535	2021/08/21-2040/11/05	發明	臺灣	邏輯 IC
969	照明源最佳化的方法	I737521	2021/08/21-2040/10/21	發明	臺灣	邏輯 IC
970	影像感測器	I737482	2021/08/21-2040/09/03	發明	臺灣	邏輯 IC
971	矽穿孔結構及其製作方法	I737523	2021/08/21-2040/10/25	發明	臺灣	邏輯 IC
972	非揮發性記憶體結構及其製造方法	I737507	2021/08/21-2040/09/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
973	記憶體的電容結構與其製作方法	I737537	2021/08/21-2040/11/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	專利證號	專利期間	類別	註冊地	分類
974	測試鍵結構及其製造方法	I737561	2021/08/21-2041/01/03	發明	臺灣	邏輯 IC
975	相移式光掩模及其制造方法	4653433	2021/09/03-2036/04/26	發明	中國	邏輯 IC
976	从多维变量推算生产力、排程优先级、优化配置的方法	4662531	2021/09/07-2037/09/13	發明	中國	邏輯 IC
977	Semiconductor package	11121119	2021/09/14-2040/03/01	發明	美國	邏輯 IC

資料來源：該公司及其子公司提供

(B)申請中

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
1	相移式光罩及其製造方法	201610268778.X	2016/4/27	發明	中國	DRAM 生產製程
2	襯墊應力層	201710127453.4	2017/3/6	發明	中國	DRAM 生產製程
3	光掩膜及其制造方法以及曝光方法	201710128566.6	2017/3/6	發明	中國	DRAM 生產製程
4	光掩模及其制造方法	201710131022.5	2017/3/7	發明	中國	DRAM 生產製程
5	金属绝缘体金属元件的制造方法	201710153461.6	2017/3/15	發明	中國	DRAM 生產製程
6	半导体存储器装置	201710176970.0	2017/3/23	發明	中國	DRAM 生產製程
7	半導體元件及其製造方法	201710426537.8	2017/6/8	發明	中國	DRAM 生產製程
8	非易失性储存装置、非易失性存储器集成电路及操作方法	201710584841 .5	2017/7/18	發明	中國	DRAM 生產製程
9	晶圓測試多目標產能規劃系統與方法	201710822787.3	2017/9/13	發明	中國	DRAM 生產製程
10	光掩模及光掩模承载平台的维护方法	201711069037.X	2017/11/3	發明	中國	DRAM 生產製程
11	相移式光掩模及其制作方法	201711306818.6	2017/12/11	發明	中國	DRAM 生產製程
12	电源控制电路以及具备电源控制电路的逻辑电路装置	201810082394.8	2018/1/29	發明	中國	DRAM 生產製程
13	拼接式光刻製作工藝的光掩模、半色調光掩模及其制法	201810126963.4	2018/2/8	發明	中國	邏輯 IC
14	集成电路结构及其制造方法	201810203742. 2	2018/3/13	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
15	快闪存储器装置及其编程方法	201810735122.3	2018/7/6	發明	中國	DRAM 生產製程
16	影像感测器及其製造方法	201811066356.X	2018/9/13	發明	中國	邏輯 IC
17	影像感测器及其製造方法	201811195119.3	2018/10/15	發明	中國	邏輯 IC
18	非挥发性存储器结构及其制造方法	201811220344.8	2018/10/19	發明	中國	DRAM 生產製程
19	同轴导体结构、电容器及其制造方法	201811220366.4	2018/10/19	發明	中國	邏輯 IC
20	MCP0043-溝渠式電晶體結構及其製造方法	201811243094.X	2018/10/24	發明	中國	DRAM 生產製程
21	金属-氧化物-金属电容结构	201811323365.2	2018/11/8	發明	中國	邏輯 IC
22	半导体制作工艺	201811517666.9	2018/12/12	發明	中國	DRAM 生產製程
23	存储器结构及其制造方法	201811557539.1	2018/12/19	發明	中國	DRAM 生產製程
24	記憶體結構及其製造方法	201811588101.X	2018/12/25	發明	中國	DRAM 生產製程
25	非揮發性記憶體結構及其製造方法	201811632865.4	2018/12/29	發明	中國	DRAM 生產製程
26	影像感测器及其制造方法	201811432218.9	2019/1/11	發明	中國	邏輯 IC
27	静态随机存取存储器及其制作方法	201910051164.X	2019/1/18	發明	中國	DRAM 生產製程
28	影像传感器及其制造方法	201910057957.2	2019/1/22	發明	中國	邏輯 IC
29	晶片的标记方法、晶圆及晶片	201910058383.0	2019/1/22	發明	中國	DRAM 生產製程
30	半导体元件及其制造方法	201910079079.4	2019/1/28	發明	中國	DRAM 生產製程
31	存储器结构	201910096167.5	2019/1/31	發明	中國	DRAM 生產製程
32	补偿非易失存储元件编程时电荷流失与源极线偏置的方法	201910097767.3	2019/1/31	發明	中國	DRAM 生產製程
33	半导体元件及其制造方法	201910096741.7	2019/1/31	發明	中國	DRAM 生產製程
34	存储器结构及其制造方法	201910096168.X	2019/1/31	發明	中國	DRAM 生產製程
35	半导体组件及其制造方法	201910110960.6	2019/2/12	發明	中國	邏輯 IC
36	记忆体结构	201910110946.6	2019/2/12	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
37	光掩模的设计方法与半导体光刻制作工艺	201910110925.4	2019/2/12	發明	中國	DRAM 生產製程
38	记忆体元件及其制造方法	201910113773.3	2019/2/14	發明	中國	DRAM 生產製程
39	阶梯式元件及其制造方法	201910113794.5	2019/2/14	發明	中國	DRAM 生產製程
40	沟渠式隔离结构的制造方法及高压半导体元件	201910113762.5	2019/2/14	發明	中國	DRAM 生產製程
41	存储器结构及其制造方法	201910136912.4	2019/2/25	發明	中國	DRAM 生產製程
42	电阻式随机存取存储器及其制造方法	201910149502.3	2019/2/28	發明	中國	DRAM 生產製程
43	半导体离子注入机的离子源头结构	201910166841.2	2019/3/6	發明	中國	DRAM 生產製程
44	可执行人工智能运算的存储器芯片及其操作方法	201910216548.2	2019/3/21	發明	中國	DRAM 生產製程
45	影像感测器及其制造方法	201910231312.6	2019/3/26	發明	中國	邏輯 IC
46	晶片夹盘装置、晶片形变量的测量方法及半导体制造流程	201910231287.1	2019/3/26	發明	中國	DRAM 生產製程
47	基于存储器处理器的多处理架构及其操作方法	201910288360.9	2019/4/11	發明	中國	DRAM 生產製程
48	存储器结构及其制造方法	201910327486.2	2019/4/23	發明	中國	DRAM 生產製程
49	AIM SYSTEM ARCHITECTURE OPTIMIZING FOR AI PROCESSING	62/744,140	2018/10/11	發明	美國	DRAM 生產製程
50	MEMORY STRUCTURE	16/285,245	2019/2/26	發明	美國	DRAM 生產製程
51	METHOD FOR DESIGNING PHOTOMASK AND SEMICONDUCTOR PHOTOLITHOGRAPHY PROCESS	16/373,637	2019/4/3	發明	美國	DRAM 生產製程
52	MCP0043-溝渠式電晶體結構及其製造方法	107137446.0	2018/10/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
53	半導體元件的製造方法	107147418.0	2018/12/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
54	半導體封裝	108110759.0	2019/3/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
55	存储器结构	201910401267.4	2019/5/15	發明	中國	DRAM 生產製程
56	存储器结构及其制造方法	201910417590.0	2019/5/20	發明	中國	DRAM 生產製程
57	电流电压转换电路、基准电压产生电路及非挥发性半导体储存装置	201910444948.9	2019/5/27	發明	中國	DRAM 生產製程
58	具有辅助栅的闪存存储器及其制作方法	201910444569.X	2019/5/27	發明	中國	DRAM 生產製程
59	非挥发性存储器结构	201910449969.X	2019/5/28	發明	中國	DRAM 生產製程
60	半导体封装	201910450085.6	2019/5/28	發明	中國	DRAM 生產製程
61	THE NOVEL 3D NAND FLASH BY LATERAL RE-DISTRIBUTION FREE DESIGN	201910463347.2	2019/5/30	發明	中國	DRAM 生產製程
62	具有记忆体内运算架构的记忆体及其操作方法	201910547680.1	2019/6/24	發明	中國	DRAM 生產製程
63	标记的制造方法	201910664807.8	2019/7/23	發明	中國	DRAM 生產製程
64	电容单元及其制造方法	201910675399.6	2019/7/25	發明	中國	邏輯 IC
65	遮蔽栅金属氧化物半导体场效晶体管及其制造方法	201910693360.7	2019/7/30	發明	中國	邏輯 IC
66	半导体结构及其制造方法	201910715947.3	2019/8/5	發明	中國	邏輯 IC
67	頁緩衝電路與非揮發性儲存裝置	201910723047.3	2019/8/6	發明	中國	DRAM 生產製程
68	电容集成结构及其电容	201910752390 .0	2019/8/15	發明	中國	邏輯 IC
69	数模转换器、不良位数检测器及非易失性半导体存储装置	201910757229.2	2019/8/16	發明	中國	DRAM 生產製程
70	通道全環繞半導體裝置及其製造方法	201910806551.X	2019/8/29	發明	中國	邏輯 IC
71	電路架構	201910806631.5	2019/8/29	發明	中國	邏輯 IC
72	固定環	201910821982.3	2019/9/2	發明	中國	DRAM 生產製程
73	内连线结构的制造方法	201910909759.4	2019/9/25	發明	中國	DRAM 生產製程
74	用于双晶体管静态随机存取存储器的位线结构	201910976746.9	2019/10/15	發明	中國	DRAM 生產製程
75	铝层的蚀刻后保护方法	201911042647.X	2019/10/30	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
76	影像传感器	201911042630.4	2019/10/30	發明	中國	邏輯 IC
77	研磨后清洁装置	201911042646.5	2019/10/30	發明	中國	DRAM 生產製程
78	半导体结构的制造方法	201911093280.4	2019/11/11	發明	中國	DRAM 生產製程
79	非易失性半导体存储器装置及其擦除控制电路、方法	201911134622.2	2019/11/19	發明	中國	DRAM 生產製程
80	半导体结构及其制造方法	202010004398.1	2020/1/3	發明	中國	邏輯 IC
81	晶圓圖的辨識方法與電腦可讀取記錄媒體	201911355190.8	2020/1/6	發明	中國	DRAM 生產製程
82	具有隐藏的识别码的半导体堆叠结构	202010040962.5	2020/1/15	發明	中國	DRAM 生產製程
83	半导体封装	202010074748.1	2020/1/22	發明	中國	DRAM 生產製程
84	半導體封裝	202010076181.1	2020/1/23	發明	中國	DRAM 生產製程
85	电容结构以及其制作方法	202010080562.7	2020/2/5	發明	中國	邏輯 IC
86	影像感測器結構及其製造方法	202010089928.7	2020/2/13	發明	中國	邏輯 IC
87	微透鏡結構及其製造方法	202010089872.5	2020/2/13	發明	中國	邏輯 IC
88	非揮發性記憶體元件及其製造方法	202010146226.8	2020/3/5	發明	中國	DRAM 生產製程
89	存储器结构及其制造方法	202010221969.7	2020/3/26	發明	中國	邏輯 IC
90	存储器结构及其制造方法	202010221969.7	2020/3/26	發明	中國	邏輯 IC
91	半导体元件及其制造方法	202010234917.3	2020/3/30	發明	中國	邏輯 IC
92	存储器、存储器芯片以及存储器数据存取方法	202010289049.9	2020/4/14	發明	中國	DRAM 生產製程
93	失效位数目计数电路及非易失性半导体储存装置	202010311415.6	2020/4/20	發明	中國	DRAM 生產製程
94	記憶體結構的製造方法	202010330782.0	2020/4/24	發明	中國	DRAM 生產製程
95	绝缘栅极场效双极性晶体管及其制造方法	202010376705.9	2020/5/7	發明	中國	邏輯 IC
96	記憶體元件及其製造方法	202010376547.7	2020/5/7	發明	中國	DRAM 生產製程
97	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	202010385789.2	2020/5/9	發明	中國	DRAM 生產製程
98	静态随机存取存储器元件及其制造方法	202010428839.0	2020/5/20	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
99	存储器结构及其制造方法	202010466393.0	2020/5/28	發明	中國	DRAM 生產製程
100	集成电路及其制造方法	202010466375.2	2020/5/28	發明	中國	DRAM 生產製程
101	多层电容元件以及多层电容元件的设计方法	202010472946.3	2020/5/29	發明	中國	邏輯 IC
102	半导体元件的制造方法	202010498510.1	2020/6/4	發明	中國	DRAM 生產製程
103	電晶體及其製造方法	202010498516.9	2020/6/4	發明	中國	邏輯 IC
104	用于光学邻近修正的重定位方法	202010540641.1	2020/6/15	發明	中國	DRAM 生產製程
105	非揮發性記憶體結構	202010572228 .3	2020/6/22	發明	中國	DRAM 生產製程
106	半导体存储器及其部分写入方法	202010581876.5	2020/6/23	發明	中國	DRAM 生產製程
107	绝缘栅双极晶体管结构及其制造方法	202010650268.5	2020/7/8	發明	中國	邏輯 IC
108	半導體結構及其製作方法	202010679056.X	2020/7/15	發明	中國	DRAM 生產製程
109	半導體裝置及其製造方法	202010729805.5	2020/7/27	發明	中國	DRAM 生產製程
110	封装结构及其制作方法	202010781738.1	2020/8/6	發明	中國	DRAM 生產製程
111	线路末端结构及其形成方法	202010816535.1	2020/8/14	發明	中國	DRAM 生產製程
112	复合型存储器结构	202010965977.2	2020/9/15	發明	中國	DRAM 生產製程
113	半导体元件及其制造方法	202011008045.5	2020/9/23	發明	中國	DRAM 生產製程
114	3D NAND 闪存存储器元件	202011153992.3	2020/10/26	發明	中國	DRAM 生產製程
115	具有测试功能的存储器及其测试方法	202011272042.2	2020/11/13	發明	中國	DRAM 生產製程
116	METHOD FOR FABRICATING DRAM CELL CAPACITOR WITH OFFSET SIDEWALL CORRUGATING	202011303477.9	2020/11/19	發明	中國	DRAM 生產製程
117	非挥发性存储器元件及其制造方法	202011441535.4	2020/12/8	發明	中國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
118	平坦化方法	202110095422.1	2021/1/25	發明	中國	DRAM 生產製程
119	测试键结构及其制造方法	202110167909.6	2021/2/7	發明	中國	DRAM 生產製程
120	半导体结构	202110167922.1	2021/2/7	發明	中國	DRAM 生產製程
121	电容集成结构、电容单元及其制造方法	202110170859.7	2021/2/8	發明	中國	邏輯 IC
122	在设计自动化平台上进行电压规则检查的计算机实施方法	202110178210.X	2021/2/9	發明	中國	DRAM 生產製程
123	闪存储存装置及其偏压方法	202110191342.6	2021/2/19	發明	中國	DRAM 生產製程
124	電容單元及其製造方法	202110198057.7	2021/2/22	發明	中國	邏輯 IC
125	eMOAT-双向可控硅整流器	202110200794.6	2021/2/23	發明	中國	DRAM 生產製程
126	eMOAT-可控硅整流器	202110253917.2	2021/3/9	發明	中國	DRAM 生產製程
127	記憶體元件及其製造方法	202110266366.3	2021/3/11	發明	中國	DRAM 生產製程
128	测试三维集成电路中硅穿孔的电路结构	202110371035.6	2021/4/7	發明	中國	DRAM 生產製程
129	静态随机存取存储器及其操作方法	202110376066.0	2021/4/8	發明	中國	DRAM 生產製程
130	半导体装置	202110458050.4	2021/4/27	發明	中國	邏輯 IC
131	改善芯片翘曲的方法	202110458322.0	2021/4/27	發明	中國	DRAM 生產製程
132	DRAM 電容的製造方法	202110490343.0	2021/5/6	發明	中國	DRAM 生產製程
133	半导体存储器及数据保护方法	202110544192.2	2021/5/19	發明	中國	DRAM 生產製程
134	单光子发光元件与发光装置	202110563680.8	2021/5/24	發明	中國	DRAM 生產製程
135	MEMORY PROCESSOR-BASED MULTIPROCESSING ARCHITECTURE AND OPERATION METHOD THEREOF	16/503,652	2019/7/5	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
136	MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/509,516	2019/7/12	發明	美國	DRAM 生產製程
137	CAPACITOR UNIT AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/518,927	2019/7/22	發明	美國	邏輯 IC
138	WAFER CHUCK APPARATUS, METHOD FOR MEASURING WAFER BOW VALUE AND SEMICONDUCTOR PROCESS FLOW	16/518,998	2019/7/23	發明	美國	DRAM 生產製程
139	可執行人工智慧運算的記憶體晶片及其操作方法	16/548,792	2019/8/22	發明	美國	DRAM 生產製程
140	ERASE CONTROL CIRCUIT AND METHOD OF NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE, AND NON-VOLATILE SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE	16/574,099	2019/9/18	發明	美國	DRAM 生產製程
141	CHANNEL ALL AROUND SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	16/575,409	2019/9/19	發明	美國	邏輯 IC
142	SHIELD GATE MOSFET AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME	16/663,365	2019/10/25	發明	美國	邏輯 IC
143	晶圓圖的辨識方法與電腦可讀取記錄媒體	16/721,924	2019/12/20	發明	美國	DRAM 生產製程
144	被動元件-MCP0046-Capacitor	16741691.0	2020/1/13	發明	美國	邏輯 IC
145	半導體封裝	16/777,903	2020/1/31	發明	美國	DRAM 生產製程
146	MEMORY, MEMORY CHIP AND MEMORY DATA ACCESS METHOD	16/779,677	2020/2/3	發明	美國	DRAM 生產製程
147	IMAGE SENSOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/785,666	2020/2/10	發明	美國	邏輯 IC
148	半導體封裝	16/796,911	2020/2/20	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
149	MICROLENS STRCUTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREFORE	16/813,757	2020/3/10	發明	美國	邏輯 IC
150	METHOD OF MANUFACTURING PHASE-SHIFTING PHOTOMASK	16/842,776	2020/4/8	發明	美國	DRAM 生產製程
151	SOLID-STATE IMAGE SENSOR WITH PILLAR SURFACE MICROSTRUCTURE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	16/845,046	2020/4/9	發明	美國	邏輯 IC
152	MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/858,746	2020/4/27	發明	美國	DRAM 生產製程
153	SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/858,717	2020/4/27	發明	美國	邏輯 IC
154	MAXRAM-SEMICONDUCTOR MEMORY AND PARTIAL WRITING METHOD THEREOF	16/868,544	2020/5/7	發明	美國	DRAM 生產製程
155	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/869,593	2020/5/8	發明	美國	DRAM 生產製程
156	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/877,502	2020/5/19	發明	美國	邏輯 IC
157	METHOD OF MANUFACTURING MEMORY STURCTURE	16/880,937	2020/5/21	發明	美國	DRAM 生產製程
158	INSULATED GATE FIELD EFFECT BIPOLAR TRANSISTOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/883,997	2020/5/26	發明	美國	邏輯 IC
159	IMAGE SENSING MODULE	16/898,412	2020/6/10	發明	美國	邏輯 IC
160	A Multi-layer Capacitor Device，多層電容結構與製造方法	16/905,926	2020/6/19	發明	美國	邏輯 IC
161	電晶體及其製造方法	16/916,044	2020/6/29	發明	美國	邏輯 IC
162	MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE	16/921,946	2020/7/7	發明	美國	DRAM 生產製程
163	SEMICONDUCTOR PATTERNING PROCESS	16/924,131	2020/7/8	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
164	INTEGRATED CIRCUIT AND METHOD OF MANUFACTURING SAME	16/925,308	2020/7/9	發明	美國	DRAM 生產製程
165	MEMORY STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/926,760	2020/7/12	發明	美國	DRAM 生產製程
166	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	16/931,411	2020/7/16	發明	美國	DRAM 生產製程
167	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	16/942,731	2020/7/29	發明	美國	DRAM 生產製程
168	MEMORY STRUCTURE	16/944,162	2020/7/31	發明	美國	DRAM 生產製程
169	缺陷辨識方法以及影像分析系統	16/993,294	2020/8/14	發明	美國	DRAM 生產製程
170	絕緣閘雙極電晶體結構及其製造方法	17/000,371	2020/8/24	發明	美國	邏輯 IC
171	SEMICONDUCTOR STRUCTURE AND INTEGRATED CIRCUIT	17/008,642	2020/9/1	發明	美國	DRAM 生產製程
172	具有測試功能的記憶體及其測試方法	17/015,086	2020/9/9	發明	美國	DRAM 生產製程
173	THE NOVEL METHOD OF CONTROL AIR GAP RATIO FORMATION	17/019,328	2020/9/13	發明	美國	DRAM 生產製程
174	一種減少位元線偶合的半導體結構與其製造方法	17/024,717	2020/9/18	發明	美國	DRAM 生產製程
175	HYBRID MEMORY STRUCTURE	17/033,945	2020/9/28	發明	美國	DRAM 生產製程
176	MEMORY STRUCTURE	17/075,705	2020/10/21	發明	美國	DRAM 生產製程
177	MEMORY STRUCTURE	17/075,708	2020/10/21	發明	美國	DRAM 生產製程
178	NON-VOLATILE MEMORY STRUCTURE	17/093,585	2020/11/9	發明	美國	DRAM 生產製程
179	ANALYSIS METHOD AND ANALYSIS SYSTEM OF VOLTAGE CONTRAST DEFECT	17/092,324	2020/11/9	發明	美國	DRAM 生產製程
180	3D NAND FLASH MEMORY DEVICE	16/952,078	2020/11/19	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
181	MEMORY STRUCTURE	17/115,811	2020/12/9	發明	美國	DRAM 生產製程
182	METHOD OF MANUFACTURING TRENCH TRANSISTOR STRUCTURE	17/115,799	2020/12/9	發明	美國	DRAM 生產製程
183	PHASE SHIFT MASK AND MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE	17/120,278	2020/12/14	發明	美國	DRAM 生產製程
184	NON-VOLATILE MEMORY DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	17/144,101	2021/1/7	發明	美國	DRAM 生產製程
185	MANUFACTURING METHOD OF IMAGE SENSOR	17/145,413	2021/1/11	發明	美國	邏輯 IC
186	SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	17/147,476	2021/1/13	發明	美國	DRAM 生產製程
187	PLANARIZATION METHOD	17/160,402	2021/1/28	發明	美國	DRAM 生產製程
188	MEMORY STRUCTURE	17/182,149	2021/2/22	發明	美國	DRAM 生產製程
189	CAPACITOR STRUCTURES FOR MEMORY AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	17/202,301	2021/3/15	發明	美國	DRAM 生產製程
190	FINGERPRINT SENSING SYSTEM	17/203,725	2021/3/16	發明	美國	邏輯 IC
191	FLASH MEMORY STORAGE APPARATUS AND A BIASING METHOD THEREOF	17/204,955	2021/3/18	發明	美國	DRAM 生產製程
192	SEMICONDUCTOR MEMORY AND DATA PROTECTION METHOD	17/206,141	2021/3/19	發明	美國	DRAM 生產製程
193	DUAL-DIRECTIONAL SILICON-CONTROLLED	17/210,520	2021/3/24	發明	美國	DRAM 生產製程
194	SILICON-CONTROLLED RECTIFIER	17/218,168	2021/3/31	發明	美國	DRAM 生產製程
195	METHOD FOR MANUFACTURING METAL OXIDE SEMICONDUCTOR TRANSISTOR	17/226,097	2021/4/9	發明	美國	DRAM 生產製程
196	靜態隨機存取記憶體及其操作方法	17/229,823	2021/4/13	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
197	SEMICONDUCTOR MEMORY WITH TEMPERATURE DEPENDENCE	17/306,918	2021/5/3	發明	美國	DRAM 生產製程
198	DRAM 電容的製造方法	17/308,072	2021/5/5	發明	美國	DRAM 生產製程
199	SEMICONDUCTOR PACKAGE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	17/319,119	2021/5/13	發明	美國	DRAM 生產製程
200	SUB-SENSE AMPLIFIER AND SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE	17/342,565	2021/6/9	發明	美國	DRAM 生產製程
201	MULTI-LAYER CAPACITOR UNIT AND MANUFACTURING PROCESS THEREOF	17352255.0	2021/6/19	發明	美國	邏輯 IC
202	具有記憶體內運算架構的記憶體及其操作方法	108119618.0	2019/6/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
203	膜厚量測系統及膜厚量測方法	108125590.0	2019/7/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
204	通道全環繞半導體裝置及其製造方法	108125557.0	2019/7/19	發明	臺灣	邏輯 IC
205	記憶體結構及其製造方法	108127748.0	2019/8/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
206	固定環	108128172.0	2019/8/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
207	半導體結構及其製造方法	108146564.0	2019/12/19	發明	臺灣	邏輯 IC
208	半導體封裝	109100303.0	2020/1/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
209	影像感測器結構及其製造方法	109101139.0	2020/1/14	發明	臺灣	邏輯 IC
210	電容結構以及其製作方法	109102061.0	2020/1/21	發明	臺灣	邏輯 IC
211	非揮發性記憶體元件及其製造方法	109105454.0	2020/2/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
212	半導體元件及其製造方法	109108160.0	2020/3/12	發明	臺灣	邏輯 IC
213	半導體裝置	109108746.0	2020/3/17	發明	臺灣	邏輯 IC
214	非揮發性記憶體元件	109111126.0	2020/4/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
215	氣動元件用的供氣洩漏偵測系統	109111257.0	2020/4/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
216	氣體噴灑裝置、半導體基板處理設備及其操作方法	109111447.0	2020/4/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
217	半導體結構及其製造方法	109112408.0	2020/4/13	發明	臺灣	邏輯 IC
218	靜態隨機存取記憶體元件及其製造方法	109113251.0	2020/4/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
219	半導體元件及其製造方法	109114255.0	2020/4/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
220	半導體圖案化製程	109114871.0	2020/5/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
221	半導體結構及其製造方法	109114881.0	2020/5/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
222	圖案化方法	109114883.0	2020/5/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
223	記憶體結構及其製造方法	109115448.0	2020/5/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
224	積體電路及其製造方法	109115449.0	2020/5/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
225	非揮發性記憶體結構	109116212.0	2020/5/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
226	光罩的形成方法及離子植入罩幕的製造方法	109116213.0	2020/5/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
227	電晶體及其製造方法	109116418.0	2020/5/18	發明	臺灣	邏輯 IC
228	半導體製程用游標尺及使用其進行的微影製程檢測方法	109116487.0	2020/5/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
229	半導體元件及其製造方法	109116476.0	2020/5/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
230	用於光學鄰近修正的重定位方法	109117643.0	2020/5/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
231	半導體元件的製造方法	109119490.0	2020/6/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
232	半導體記憶體及其部分寫入方法	109119486.0	2020/6/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
233	晶圓處理方法及晶圓固持裝置	109120750.0	2020/6/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
234	缺陷辨識方法以及影像分析系統	109122218.0	2020/7/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
235	非揮發性記憶體結構	109122202.0	2020/7/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程
236	半導體結構及其製作方法	109122239.0	2020/7/1	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
237	影像感測裝置	109123713.0	2020/7/14	發明	臺灣	邏輯 IC
238	廢磷酸液回收系統與方法	109124412.0	2020/7/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
239	電晶體結構及其製造方法	109124671.0	2020/7/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
240	封裝結構及其製作方法	109124926.0	2020/7/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
241	半導體製程控制系統及半導體製程控制方法	109125394.0	2020/7/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
242	THE NOVEL METHOD OF CONTROL AIR GAP RATIO FORMATION	109126234.0	2020/8/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
243	電壓對比缺陷的分析方法及分析系統	109126588.0	2020/8/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
244	A HV DEVICE WITH VERTICALLY EXTENDED DRIFT REGION	109127948.0	2020/8/17	發明	臺灣	邏輯 IC
245	A DEVICE CORRELATED ION IMPLANTATION CONTROL METHOD (MACHINE LEARNING)	109128635.0	2020/8/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
246	一種減少位元線偶合的半導體結構與其製造方法	109128793.0	2020/8/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
247	記憶體的讀取方法	109129436.0	2020/8/28	發明	臺灣	DRAM 生產製程
248	複合型記憶體結構	109130199.0	2020/9/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
249	影像感測器	109130305.0	2020/9/4	發明	臺灣	邏輯 IC
250	BL LINE END FORMATION METHOD	109131160.0	2020/9/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
251	減少淺溝渠隔離結構邊緣凹陷的方法	109132833.0	2020/9/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
252	鉑的圖案化方法	109132823.0	2020/9/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
253	晶圓盒搬運夾具	109134042.0	2020/9/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
254	非揮發性記憶體結構及其製造方法	109134000.0	2020/9/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
255	試片製備方法及試片製備系統	109134522.0	2020/10/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
256	3D NAND 快閃記憶體元件	109134727.0	2020/10/7	發明	臺灣	DRAM 生產製程
257	擺盪曲線的產生方法	109135504.0	2020/10/14	發明	臺灣	DRAM 生產製程
258	照明源最佳化的方法	109136601.0	2020/10/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
259	矽穿孔結構及其製作方法	109137019.0	2020/10/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
260	具有測試功能的記憶體及其測試方法	109137677.0	2020/10/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
261	半導體裝置及其製造方法	109138932.0	2020/11/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
262	鉑的圖案化方法	109138933.0	2020/11/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
263	記憶體的電容結構與其製作方法	109139096.0	2020/11/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
264	密合度偵測系統及密合度偵測方法	109139483.0	2020/11/12	發明	臺灣	DRAM 生產製程
265	半導體加工的方法及製具	109140047.0	2020/11/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
266	相移遮罩及半導體元件的製作方法	109140049.0	2020/11/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
267	非揮發性記憶體元件及其製造方法	109140994.0	2020/11/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
268	導線結構的製造方法	109141703.0	2020/11/27	發明	臺灣	DRAM 生產製程
269	半導體裝置及其製造方法	109143094.0	2020/12/7	發明	臺灣	DRAM 生產製程
270	OPTIMIZATION NS300 AS2 NOZZLE WATERPROOF COVER	109143169.0	2020/12/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
271	資料儲存裝置與資料儲存裝置的控制方法	109144169.0	2020/12/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
272	金屬-絕緣體-金屬電容結構及其製作方法	110100003.0	2021/1/4	發明	臺灣	邏輯 IC
273	半導體裝置及其製造方法	110100074.0	2021/1/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
274	影像感測器及其製造方法	110100075.0	2021/1/4	發明	臺灣	邏輯 IC

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
275	測試鍵結構及其製造方法	110100031.0	2021/1/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
276	金屬氧化物半導體電晶體的製造方法	110100060.0	2021/1/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
277	平坦化方法	110100051.0	2021/1/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
278	管理方法及生產系統	110100413.0	2021/1/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
279	半導體結構	110100849.0	2021/1/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
280	半導體結構	110100849.0	2021/1/8	發明	臺灣	DRAM 生產製程
281	半導體元件的主動區域的製作方法	110101278.0	2021/1/13	發明	臺灣	DRAM 生產製程
282	對位結構及其形成方法	110101701.0	2021/1/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
283	電容集成結構、電容單元及其製造方法	110102113.0	2021/1/20	發明	臺灣	邏輯 IC
284	用以定義閘介電層的光罩的布局設計方法	110102427.0	2021/1/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
285	電容單元及其製造方法	110103641.0	2021/2/1	發明	臺灣	邏輯 IC
286	在電子設計自動化平台上進行電壓規則檢查的電腦實施方法	110103821.0	2021/2/2	發明	臺灣	DRAM 生產製程
287	非揮發性記憶體結構及其製造方法	110103817.0	2021/2/2	發明	臺灣	DRAM 生產製程
288	記憶體元件及其製造方法	110103988.0	2021/2/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
289	修整半導體結構的方法	110104037.0	2021/2/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
290	快閃記憶體儲存裝置及其偏壓方法	110104200.0	2021/2/4	發明	臺灣	DRAM 生產製程
291	指紋感測系統	110104177.0	2021/2/4	發明	臺灣	邏輯 IC
292	警示方法及警示系統	110104343.0	2021/2/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
293	測試半導體圖案的方法	110106660.0	2021/2/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
294	背照式影像感測器及其製造方法	110107227.0	2021/3/2	發明	臺灣	邏輯 IC

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
295	靜態隨機存取記憶體及其操作方法	110107514.0	2021/3/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程
296	半導體裝置及其製造方法	110107873.0	2021/3/5	發明	臺灣	DRAM 生產製程
297	液體供應系統及液量輔助判斷方法	110109268.0	2021/3/16	發明	臺灣	DRAM 生產製程
298	半導體圖案的生成方法	110109544.0	2021/3/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
299	半導體封裝及其製造方法	110109889.0	2021/3/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
300	半導體裝置及其製造方法	110109891.0	2021/3/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
301	閘介電層的製造方法	110110413.0	2021/3/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
302	測試三維積體電路中矽穿孔的電路結構	110110430.0	2021/3/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
303	eMOAT-雙向矽控整流器	110110505.0	2021/3/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
304	背照式影像感測器及其製造方法	110110921.0	2021/3/25	發明	臺灣	邏輯 IC
305	半導體裝置	110110894.0	2021/3/25	發明	臺灣	邏輯 IC
306	半導體元件及其製造方法	110111199.0	2021/3/26	發明	臺灣	DRAM 生產製程
307	半導體裝置的缺陷分析方法與電子裝置	110111694.0	2021/3/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
308	具有保全功能的半導體裝置及其保全方法	110111434.0	2021/3/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
309	矽控整流器	110111750.0	2021/3/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
310	深溝渠式電容器及其製造方法	110112684.0	2021/4/8	發明	臺灣	邏輯 IC
311	改善晶圓翹曲的方法	110113902.0	2021/4/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
312	非揮發性記憶體裝置及其程式化驗證電壓的設定方法	110114284.0	2021/4/21	發明	臺灣	DRAM 生產製程
313	沉積製程控制方法	110115545.0	2021/4/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
314	半導體記憶體及資料保護方法	110115948.0	2021/5/3	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
315	單光子發光元件與發光裝置	110116391.0	2021/5/6	發明	臺灣	DRAM 生產製程
316	電晶體結構及其製造方法	110116678.0	2021/5/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
317	感測電路以及測試裝置	110117683.0	2021/5/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
318	非揮發性記憶體結構	110117737.0	2021/5/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
319	記憶體裝置	110119697.0	2021/5/31	發明	臺灣	DRAM 生產製程
320	次級感測放大器與半導體記憶裝置	110120949.0	2021/6/9	發明	臺灣	DRAM 生產製程
321	電晶體結構與記憶體結構	110121650.0	2021/6/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
322	旋鈕式化學晶舟	110121692.0	2021/6/15	發明	臺灣	DRAM 生產製程
323	晶圓堆疊結構及其製造方法	110122035.0	2021/6/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程
324	半導體結構以及其形成方法	110122309.0	2021/6/18	發明	臺灣	邏輯 IC
325	具有溫度依存性的半導體記憶體	110122754.0	2021/6/22	發明	臺灣	DRAM 生產製程
326	晶圓搜尋方法及裝置	110122947.0	2021/6/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
327	半導體電容結構	110122953.0	2021/6/23	發明	臺灣	邏輯 IC
328	半導體封裝	110123375.0	2021/6/25	發明	臺灣	DRAM 生產製程
329	晶圓清洗刷	110124078.0	2021/6/30	發明	臺灣	DRAM 生產製程
330	人工知能動作を実行できるメモリチップおよびその方法	2019-171109	2019/9/20	發明	日本	DRAM 生產製程
331	回路構造	2019-235821	2019/12/26	發明	日本	邏輯 IC
332	全周チャンネル型半導体装置およびその製造方法	2020-002688	2020/1/10	發明	日本	邏輯 IC
333	IV CONVERTOR WITH WIDE RANGE CURRENT MIRROR AND USAGE ON FLASH MEMORY	2020-203224	2020/12/8	發明	日本	DRAM 生產製程
334	半導體封裝	10-2020-0026437	2020/3/3	發明	韓國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
335	半導體封裝	10-2020-0037749	2020/3/27	發明	韓國	DRAM 生產製程
337	次级感测放大器与半导体存储装置	202110702813.5	2021/06/24	發明	中國	DRAM 生產製程
338	晶体管结构与存储器结构	202110733744.4	2021/06/30	發明	中國	邏輯 IC
339	传感电路以及测试装置	202110742336.5	2021/07/01	發明	中國	邏輯 IC
340	晶片堆叠结构及其制造方法	202110742302.6	2021/07/01	發明	中國	邏輯 IC
341	良率導向之線上機台匹配管理方法	110124551	2021/07/05	發明	臺灣	邏輯 IC
342	晶圓清洗系統與晶圓清洗方法	110124650	2021/07/05	發明	臺灣	邏輯 IC
343	半导体结构以及其形成方法	202110760448.3	2021/07/06	發明	中國	邏輯 IC
344	非揮發性記憶體裝置及其讀取驗證電壓的決定方法	110125182	2021/07/08	發明	臺灣	DRAM 生產製程
345	電子裝置及其製作方法	110125181	2021/07/08	發明	臺灣	邏輯 IC
346	具有温度依存性的半导体存储器	202110776607.9	2021/07/09	發明	中國	邏輯 IC
347	晶片搜寻方法及装置	202110783217.4	2021/07/12	發明	中國	邏輯 IC
348	半導體元件及其操作方法	110125574	2021/07/12	發明	臺灣	邏輯 IC
349	堆疊半導體元件的製造方法	110125427	2021/07/12	發明	臺灣	邏輯 IC
350	存储器装置	202110783538.4	2021/07/12	發明	中國	DRAM 生產製程
351	COMPUTER-IMPLEMENTED METHOD OF PERFORMING VOLTAGE RULE CHECK IN AN ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION PLATFORM	17/373,790	2021/07/13	發明	美國	邏輯 IC
352	CIRCUIT STRUCTURE FOR TESTING THROUGH SILICON VIAS IN THREE- DIMENSIONAL INTEGRATED CIRCUIT	17/373,803	2021/07/13	發明	美國	邏輯 IC
353	半导体封装	202110804724.1	2021/07/16	發明	中國	邏輯 IC
354	記憶體結構	110126347	2021/07/19	發明	臺灣	DRAM 生產製程
355	TRANSISTOR STRUCTURE AND MEMORY STRUCTURE	17/378,786	2021/07/19	發明	美國	邏輯 IC
356	半導體鍵合結構	110126462	2021/07/19	發明	臺灣	邏輯 IC
357	半導體裝置	110126613	2021/07/20	發明	臺灣	DRAM 生產製程
358	光罩以及內連線結構的製造方法	110127646	2021/07/28	發明	臺灣	邏輯 IC

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
359	SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	17/386,565	2021/07/28	發明	美國	邏輯 IC
360	鐵電記憶體結構	110127876	2021/07/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程
361	晶圓結構及其製造方法	110128096	2021/07/30	發明	臺灣	邏輯 IC
362	CAPACITOR UNIT AND MANUFACTURING PROCESS THEREOF	17390987	2021/08/01	發明	美國	邏輯 IC
363	SENSING CIRCUIT AND TEST DEVICE	17/392,273	2021/08/03	發明	美國	邏輯 IC
364	背照式影像感測器及其製造方法	110128572	2021/08/03	發明	臺灣	邏輯 IC
365	半導體裝置及其製造方法	110128571	2021/08/03	發明	臺灣	DRAM 生產製程
366	THROUGH SILICON VIA AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	17/394,372	2021/08/04	發明	美國	邏輯 IC
367	WAFER STACKING STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	17/396,776	2021/08/09	發明	美國	邏輯 IC
368	OSCILLATOR CIRCUIT	17/396,771	2021/08/09	發明	美國	邏輯 IC
369	記憶體結構	110129528	2021/08/10	發明	臺灣	DRAM 生產製程
370	Semiconductor bonding structure	17/398,017	2021/08/10	發明	美國	邏輯 IC
371	升壓時脈產生器	110129848	2021/08/12	發明	臺灣	邏輯 IC
372	SEMICONDUCTOR PACKAGE	17/402,618	2021/08/16	發明	美國	邏輯 IC
373	半導體裝置及其製造方法	110130174	2021/08/16	發明	臺灣	邏輯 IC
374	FERROELECTRIC MEMORY STRUCTURE	17/403,871	2021/08/16	發明	美國	DRAM 生產製程
375	晶片结构及其制造方法	202110941145.1	2021/08/17	發明	中國	邏輯 IC
376	存储器结构	202110966714.8	2021/08/23	發明	中國	DRAM 生產製程
377	提高邊界虛擬記憶體陣列的本質臨界電壓的方法	110131156	2021/08/23	發明	臺灣	DRAM 生產製程
378	緩解邊界虛擬記憶體過抹除現象的結構與方法	110131338	2021/08/24	發明	臺灣	DRAM 生產製程
379	FAILURE BIT COUNT CIRCUIT FOR MEMORY AND METHOD THEREOF	17/412,289	2021/08/26	發明	美國	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
380	半導體製程的生產排程估測方法以及系統	110131566	2021/08/26	發明	臺灣	邏輯 IC
381	BACKSIDE ILLUMINATED IMAGE SENSOR AND MANUFACTURING METHOD THEREFORE	17/458,586	2021/08/27	發明	美國	邏輯 IC
382	升压时钟产生器	202110993701.X	2021/08/27	發明	中國	邏輯 IC
383	半导体装置及其制造方法	202111009605.3	2021/08/31	發明	中國	邏輯 IC
384	遠紅外線感測元件以及包含其的感測器	110132342	2021/08/31	發明	臺灣	邏輯 IC
385	WAFER SEARCHING METHOD AND DEVICE	17/463,562	2021/09/01	發明	美國	邏輯 IC
386	背照式影像传感器及其制造方法	202111018910.9	2021/09/01	發明	中國	邏輯 IC
387	铁电存储器结构	202111018905.8	2021/09/01	發明	中國	DRAM 生產製程
388	半導體結構以及其形成方法	110132665	2021/09/02	發明	臺灣	邏輯 IC
389	半導體結構的製造方法	110132668	2021/09/02	發明	臺灣	邏輯 IC
390	提高边界虚拟存储器阵列的本质临界电压的方法	202111036927.0	2021/09/06	發明	中國	DRAM 生產製程
391	記憶體結構及其製造方法	110132983	2021/09/06	發明	臺灣	DRAM 生產製程
392	存储器结构	202111058786.9	2021/09/08	發明	中國	DRAM 生產製程
393	MEMORY STRUCTURE	17/469,898	2021/09/09	發明	美國	DRAM 生產製程
394	浮置閘極的製造方法	110133575	2021/09/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
395	基於氧化物半導體的鐵電記憶體	110133488	2021/09/09	發明	臺灣	DRAM 生產製程
396	WAFER STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	17/472,564	2021/09/10	發明	美國	邏輯 IC
397	半導體元件的製造方法	10133929	2021/09/11	發明	臺灣	邏輯 IC
398	振盪器電路	110133896	2021/09/11	發明	臺灣	邏輯 IC
399	缓解边界虚拟存储器过抹除现象的结构与方法	202111066995.8	2021/09/13	發明	中國	DRAM 生產製程
400	半導體裝置及其製造方法	110134959	2021/09/17	發明	臺灣	DRAM 生產製程

項次	名稱	申請號	申請日期	類別	註冊地	分類
401	OXIDE SEMICONDUCTOR-BASED FRAM	17/486,871	2021/09/27	發明	美國	DRAM 生產製程
402	反熔絲結構	110136168	2021/09/29	發明	臺灣	DRAM 生產製程

資料來源：該公司及其子公司提供

B.商標權

國別	取得	申請中	合計
臺灣	3	—	3
歐盟	1	—	1
新加坡	1	—	1
美國	1	—	1
中國	3	—	3
日本	1	—	1
合計	10	—	10

資料來源：該公司及其子公司提供

截至送件日止已取得及申請中之商標權列示如下：

(A)已取得

項次	專用期限	證書號碼	商標圖樣	申請國家
1	2019/07/16-2029/07/15	7997927	PSMC	臺灣
2	2019/09/16-2029/09/15	2011795		
3	2019/09/16-2029/09/15	2011970		
4	2020/07/14-2030/07/13	18182117		歐盟
5	2020/01/17-2030/01/16	40202001283Y		新加坡
6	2021/03/09-2031/03/08	6286009		美國
7	2021/04/07-2031/04/06	41164671		中國
8	2021/01/28-2031/01/27	41164670		
9	2021/01/28-2031/01/27	41164669		
10	2021/06/21-2031/06/21	6404976		日本

資料來源：該公司及其子公司提供

(7)重要技術合作契約對申請公司及其子公司之營運風險

以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，就其產品生產開發技術之層次、來源、確保與提升，暨現在主要產品之競爭優勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃、預計生產時程及成本、市場定位、需求及未來營收效益預測達成可能性及研究發展之內部控制暨保全措施。

A.產品生產開發技術之層次、來源

該公司及其子公司長期耕耘於半導體晶圓代工服務，透過 Open Foundry 營運模式，從晶片設計到製造服務，可根據不同的屬性和需求，提供客戶所需之代工服務，藉此與客戶建立緊密及彈性的合作機制。藉由活化成熟生產技術並善用製程優勢，該公司及其子公司得以提供大規模高性價比之產品技術。所提供的製程技術及製造解決方案，包括邏輯暨特殊應用以及記憶體兩大群組產品之代工技術：

(A)邏輯暨特殊應用產品之代工技術

摩爾定律在 28 奈米節點之後，提升幅度減緩顯示先進邏輯製程不是市場唯一方向，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊應用製程(應用於顯示驅動 IC、分離式元件、電源管理晶片、CMOS 影像感測器、嵌入式非揮發記憶體之製造)及多元代工合作模式，以有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是該公司及其子公司的競爭策略，28 奈米以上成熟製程市場依然有相當大的規模，包括 IoT、工業、汽車電子等應用。隨著智慧型手機產品的普遍及人工智慧相關產品的推出，促使物聯網(IoT)產業鏈逐漸成形，更帶動上下游相關元件需求。在消費性終端產品「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，對專業晶圓代工廠而言，能提供客戶客製化製程開發更形重要。

a.高壓製程(High Voltage)

應用於手機、筆記型電腦、平板、TV 及電腦螢幕等電子產品的面板顯示驅動 IC。由於新冠肺炎疫情的關係居家上班與遠距教學成為新常態，筆記型電腦/平板電腦需求增加，加上 4K/8K 電視的滲透率上升，造成驅動 IC 需求增加、缺貨、價格上漲。該公司及其子公司將 8 吋大面板驅動 IC 高壓製程移植到 12 吋廠生產，為臺灣地區主要在 12 吋晶圓廠生產大面板驅動 IC 之晶圓代工廠，晶粒生產成本可大幅降低 30%。

b.分離式元件(Discrete)

應用在各類產品如手機/平板電池保護、PC/NB 主機板、工具機、USB、訊號開關、馬達驅動及 LED lighting 等。5G 商轉全球正式邁入 5G 世代，相較於 4G，5G 基站的 MOSFET 需求成長大於 4 倍，該公司及其子公司除 8 吋擴廠外、亦開始著手 12 吋廠開始分離式元件平台，目前亦為臺灣主要在 12 吋晶圓廠建立此產品線之晶圓代工廠。

c.CMOS 影像感測器

目前以 CIS 製程為客戶生產高解析度之影像感測晶片，並自行開發後段彩色濾光膜(color filter)與微鏡頭(micro lens)製程，以提供客戶更全面的 CIS 代工服務。智慧型手機鏡頭微 CMOS 影像感測器最大需求來源，手機使用鏡頭逐年增加目前已經來到平均單隻手機有四顆鏡頭；加上各國安防監控影像感測器需求亦持續上升，特別是在大陸地區。該公司及其子公司與國際大廠合作，在手機輔助鏡頭、安全監控器及車用行車紀錄器、倒車輔助等應用的晶片代工市占率遠遠高於其他晶圓代工競爭者。

d.電源管理製程(Power Management)

應用在各類 Power IC，如手機 PMIC、Charger、LDO、Boost converter、LED lighting、AD/DC、HV motor driver。2019~2021 年各國開始全力支援 5G 商轉，5G 技術以高速傳輸、低延遲、大量連網為特色。除了 5G 基礎建設帶動的商機，也將引發終端設備新一波的升級換機需求。相對 4G 手機，5G 手機 PMIC 使用顆數是 4~5 倍，晶片用量則是 2.5~3 倍。該公司及其子公司與世界大廠合作，率先在 12 吋生產手機用 PMIC 晶片，並與客戶共同開發下一代電源管理製程。

e.嵌入式非揮發記憶體(Embedded NVM)

應用消費性電子、工程及車用電子等。因人工智慧技術及效能的提升，物聯網及 5G 行動通訊建設臻於完善，興起許多新型態終端產品，使晶片設計複雜度不斷提昇；除追求晶片功能整合及低功耗外，還需考慮生產效能或是進一步要求半導體製程技術微縮。目前除了提供 110nm~55nm 製程平台且進入量產之外，亦積極開發 40nm 製程平台，提供客戶更低功耗、更小單位元件面積之產品。

(B)記憶體產品之代工技術

a.動態隨機存取記憶體(DRAM)

該公司及其子公司在 DRAM 代工領域深耕多年，為目前業界少數可提供 12 吋先進 DRAM 製程的代工廠商。目前除了 45nm 等成熟製程外，更積極協助客戶導入 38nm 及 25nm 製程，以滿足產品多樣化的需求。

b.快閃記憶體(NAND/NOR Flash)

該公司及其子公司多年累積快閃記憶體產品技術成果，在 NAND Flash 方面目前已提供 40nm 及 28nm 代工製程與產品設計服務。而 24nm 製程也已進入試產階段。

NOR Flash 方面，目前已提供客戶 90nm 製程 NOR Flash 代工，48nm 製程已於 2020 年進入試產階段，並於 2021 年進入量產將更具成本優勢。

B.技術之確保與提升

該公司及其子公司係以自行研發的製程技術、營業秘密、相關 know-how 維持在半導體製造業的優勢，為保護公司研發成果及技術之智慧財產權，各階段之研發文件及資料皆上傳至有授權管制之文件管理系統中，並且將新產品相關製程之研發成果申請專利權保護。該公司及其子公司除透過內部課程自行培育研發人才外，亦透過與共同開發夥伴密切合作、與工研院及學校合作，確保產品技術持續提升。

C.現在主要產品之競爭優勢、生命週期及持續發展性

(A)主要產品之競爭優勢

該公司及其子公司之代工技術分為邏輯暨特殊應用以及記憶體兩大群組產品，以下就主要產品分析其競爭優勢：

a.邏輯暨特殊應用產品晶圓代工業務

一般 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，該公司及其子公司能提供低成本的 12 吋鋁製程平台，相較同樣產品製程技術的 8 吋鋁製程，該公司及其子公司 12 吋鋁製程所產出之最後產品晶片成本可降低 30%以上，大幅提升客戶產品競爭力。

該公司及其子公司著重在 IoT、工業、汽車電子等特殊應用產品市場，以優良邏輯製程及技術提供多樣客製化特殊製程及多元代工合作模式，有效縮短客戶生產流程並提升客戶競爭優勢是該公司及其子公司的競爭策略。

(a)高壓製程(High Voltage)

該公司及其子公司提供低成本的 12 吋鋁製程 150nm~80nm 高壓製程平台用於大小面板驅動 IC 產品，有別於一般 12 吋標準邏輯晶圓代工皆為銅製程為主，相較同業產品製程技術的 8 吋鋁製程，該公司及其子公司晶粒成本可大幅降低 30%以上。此外，小面板驅動 IC 需要內建靜態隨機存取記憶體(SRAM)，記憶體之單位元件大小會影響到產品晶片大小與成本，該公司及其子公司提供之 55nm~40nm 高壓製程平台之 SRAM 記憶體之單位元件與競爭對手對比相當的競爭力。

(b)分離式元件(Discrete)

該公司及其子公司著手於 12 吋廠開發分離式元件平台，亦為目前臺灣主要在 12 吋晶圓廠建立此產品線之晶圓代工廠，相較同樣產品製程技術的 6 吋及 8 吋製程，該公司及其子公司所產出之最後產品晶片成本可降低 30%以上。

(c)CMOS 影像感測器

該公司及其子公司 CIS 影像感測器平台，提供低成本、低耗電、高穩定性及整合性高等優勢，平均良率高於 97%。

(d)電源管理製程(Power Management)

該公司及其子公司憑藉技術優勢，積極開發拓展各節點類比電源管理晶片平台以符合市場與客戶需求。數位電路面積降為競爭對手 1/4，類比電路面積降為競爭對手 9/10。

(e)嵌入式非揮發記憶體製程(Embedded NVM)

該公司及其子公司 eFlash 採用新一代 Flash 架構，需要額外光罩層數與最大電壓，均優於競爭對手。

b.記憶體晶圓代工業務

(a)動態隨機存取記憶體(DRAM)

該公司及其子公司 DRAM 記憶體代工產品線有別於其他 IDM 廠，為目前全球主要能提供客製化 DRAM 產品及完整優化製程服務的公司，為記憶體 IC 設計公司缺一不可的重要合作夥伴。

(b)快閃記憶體(NAND/NOR Flash)

該公司及其子公司多年累積快閃記憶體產品技術成果，在 NAND Flash 方面，提供 40nm 及 28nm 代工製程與產品設計服務。鎖定行動通訊應用裝置、消費性電子產品、汽車聯網、及工業應用市場，提供低功率節能及高可靠度的 NAND Flash 產品。在 NOR Flash 方面，該公司及其子公司 12 吋晶圓廠機台配置用於生產 NOR Flash 及具成本優勢。

(B)生命週期及持續發展性

半導體晶片終端應用產品非常廣泛，惟隨著各項電子終端產品要求「輕、薄、長、效」趨勢訴求下，終端產品生命週期縮短也影響著半導體製造晶圓生命週期持續縮短，半導體製程技術密集度也越來越高，該公司及其子公司除強化自身產品技術線外，持續往下一代先進製程進行開發，同時也加強既有之成熟製程能力。受惠於車用、5G、人工智慧物聯網(AIoT)等終端應用快速興起，晶圓代工需求強勁，對全球半導體產業造成結構性的改變，目前市場對成熟製程的晶片需求出現大爆發的情況，未來供不應求將更嚴重。

D.新產品之研究開發計畫、預計生產時程及成本

該公司及其子公司為因應 5G 基地台、車用元件及物聯網市場，制定多項研發計畫，透過過往經驗與生產製造能力，預計研發多項邏輯暨特殊應用產品代工及記憶產品代工技術，並以該公司及其子公司原有核心技術為基礎，逐步

推進先進製程以發展至各種產品之應用技術。該合併公司每年約投入營業收入之 7%作為研究開發經費。茲將目前研發項目及預訂時程列示如下：

研發項目	說明
55nm L55 新應用和新客戶導入	預定 2022 量產
40nm HV40 高壓製程	預定 2021 完成開發
40nm L40 邏輯製程客戶導入	預定 2022 量產
40nm eFlash (IMC40)製程	預定 2023 完成開發
38nm DRAM 55nm Logic wafer stacking 製程	預定 2021 完成開發
WOW Logic and DRAM stacking (3D Interchip)製程	預定 2022 完成開發
90nm CIS 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_BSI 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_Global Shutter 製程	預定 2021 完成開發
110nm CIS_Bio-Chop 製程	預定 2022 完成開發
21nm DRAM 8GD4 (186AD)製程	預定 2021 完成開發
25nm DRAM 4G DDR3 RDL(KGD)製程	預定 2021 完成開發
38nm DRAM embedded capacito 製程	預定 2022 完成開發
24nm NAND Flash (DK24)製程	預定 2022 完成開發
80nm BCD 1.2V(1.8V)/5V 製程	G1:5V GOX 2022 開發完成 G2:1.8V GOX 2023 開發完成
90nm BCD(SG90)	預定 2021 完成開發
130nm BCD 1.5V/5V/80V	預定 2022 完成開發
GaN on Si Power Device	預定 2023 完成開發
150nm Micro-bolometer IR Image Sensor	預定 2022 完成開發
110nm MCU	預定 2021 完成開發
110nm Data storage	預定 2021 完成開發
Discrete, MLSC LD and HD capacitor	預定 2021 完成開發

資料來源：該公司及其子公司提供

E.新產品之市場定位、需求及未來營收效益預測達成可能性

隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦。該公司及其子公司同時擁有 8 吋及 12 吋鋁製程的晶圓代工方案，成為該公司及其子公司在成熟邏輯代工業務有別於其他市場競爭者的成本規模優勢。而利基型記憶體透過與高效能且先進的邏輯晶片結合之獨特封裝技術概念，亦為市場提供一新穎且產生更大效益的代工合作方案。

半導體代工市場需求量前景樂觀，且該公司及其子公司持續擴建新廠增加產能，預計未來全球代工市場之營收規模及市占率將持續提升，未來業績成長尚屬可期。

F.研究發展之內部控制暨保全措施

該公司及其子公司已於內部控制制度中之研發循環訂有相關作業予以規範，包括基礎研究、產品設計、技術研發、產品試作及測試、智慧財產權之取得、維護及運用等作業程序及相關控制重點，以利研究發展作業有效之執行，並確保研發作業管理之落實。另於研究發展之保全措施方面，該公司及其子公司各階段之研發文件及資料皆上傳至有授權管制之文件管理系統中，按不同性質屬性建檔標示管理，且技術文件依機密程度分類建檔，應經核准後，方能取得機密文件，並設有簽收簿。研發成果移轉階段中，新產品相關製程指導規範皆由研發文件保管權責單位妥善保管。該公司及其子公司禁用私人儲存裝置、私人設備禁止拍照錄影、列印影印傳真皆有控管、到職同仁簽有保密協議。另外，該公司及其子公司設有智權室，鼓勵同仁將研發成果提出專利之申請，以保障公司研發成果之智慧財產權。

(8)以科技事業、文化創意事業或資訊軟體業申請股票上市者，其參與經營決策之董事、監察人、持股五%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近三年度及申請年度內股權移轉變化暨實際投入經營之時間與情形等，以評估該等人員未來若未能繼續參與經營對公司之營運風險，及其因應之措施

A.該公司及其子公司係以科技事業申請股票上市，設有審計委員會取代監察人職務，另該公司及其子公司並無以專利權或專門技術出資之股東，持股 5%以上之股東為力晶科技股份有限公司，茲將該公司及其子公司董事、持股 5%以上之股東及掌握生產技術與技術開發經理人等之資歷(工作經理、教育背景及職位年資)、持股比例、實際投入經營之時間與情形列示如下：

110 年 9 年 30 日；股數：股

職稱	姓名	學歷	經歷	持股股數	持股比例	產業年資	於該公司服務年資
董事長暨執行長	黃崇仁	美國紐約大學	西奈山醫學院醫學博士 力晶集團董事長 力晶科技(股)公司技術暨策略總監	115,635,061	3.40	26	3
董事 副執行長暨總經理	謝再居	美國俄亥俄州辛辛那堤電機博士	美國德州大學(Arlington)電機系副教授兼研究中心主任 力晶科技(股)公司副執行長暨先進技術總監	1,687,029	0.05	36	3
董事	仁典投資(股)公司	-	-	16,451,676	0.48	-	-
	代表人：邵章榮	國立臺灣大學國際企業碩士	力晶科技(股)公司總經理特別助理 力晶科技(股)公司副總經理	89,000	0.00	24	3
董事	力晶科技(股)公司	-	-	835,486,370	24.54	-	-
	代表人：徐清祥	美國伊利諾依大學電機系博士	國立清華大學電子研究所所長	205,032	0.01	註	註

職稱	姓名	學歷	經歷	持股股數	持股比例	產業年資	於該公司服務年資
			美國紐約州 IBM T. J.華生研究中心研究員 力旺電子股份有限公司董事長 漢芝電子(股)公司董事長 PUFsecurity USA Corporation 董事長 熵碼科技(股)公司法人董事長代表人暨總經理 安瀚科技(股)公司法人董事代表 宏碁(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 閎康科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 財團法人國家實驗研究院董事				
獨立董事	吳重雨	國立交通大學電子工程博士	國立交通大學校長 晶焱科技股份有限公司獨立董事	-	-	註	註
獨立董事	張嘉臨	美國普林斯頓電機工程博士 美國賓州大學華頓商學院MBA	美國摩托羅拉公司半導體工程師 美商高盛投資銀行全球合夥人 宏達國際電子(股)公司總經理及財務長	-	-	註	註
獨立董事	林憲銘	國立交通大學電子計算機與控制工程學士	宏碁電腦(股)公司總經理	-	-	註	註
獨立董事	林本堅	美國俄亥俄州立大學電機工程學系博士 國立臺灣大學電機工程學系學士	美國國際商用機器公司研究員、研發經理、部經理、幕僚 臺灣積體電路製造股份有限公司資深處長、傑出科技院士/副總經理 國立清華大學特聘研究講座教授 國立交通大學特聘研究講座教授 國立臺灣大學特聘研究講座教授 國立清華大學台積電聯合研發中心主任 美國領創公司總經理	-	-	註	註
獨立董事	葉疏	美國加州大學洛杉磯分校會計學博士	中華電信股份有限公司財務長暨執行副總經理 中華電信股份有限公司獨立董事 愛普科技股份有限公司獨立董事兼審計及薪酬委員 國立臺灣大學會計系教授	-	-	註	註

職稱	姓名	學歷	經歷	持股股數	持股比例	產業年資	於該公司服務年資
			捷敏股份有限公司獨立董事兼審計及薪酬委員 龍巖股份有限公司獨立董事兼審計及薪酬委員				
技術長	張守仁	國立臺灣大學電機博士	臺灣積體電路製造(股)公司副處長 力晶科技(股)公司協理	1,196,211	0.04	23	3

資料來源：該公司及其子公司提供

註：非屬該公司及其子公司員工故無年資統計

B.參與經營決策之董事、監察人、持股五%以上股東，以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術與技術開發經理人最近三年度及申請年度內股權移轉變化情形：

該公司及其子公司 107~109 年及 110 年截至 9 月 30 日止，並無以專利權或專門技術出資之股東；另該公司及其子公司參與決策之董事、持股五%以上股東及掌握生產技術與技術開發經理人等 107~109 年及 110 年截至 9 月 30 日止股權移轉變化情形，列示如下：

單位：股

職稱	姓名	106.12.31 持股數	107 年度		107.12.31 持股數	108 年度		108.12.31 持股數	109 年度		109.12.31 持股數	110 年截至第三季		110.9.30 持股數
			現增或員工認股	一般交易		現增或員工認股	一般交易		現增或員工認股	一般交易		現增或員工認股	一般交易	
董事長暨執行長	黃崇仁	-	-	-	-	4,212,306	-	4,212,306	-	101,436,485	105,648,791	9,986,270	-	115,635,061
董事/副執行長暨總經理	謝再居	-	-	-	-	613,480	-	613,480	-	625,793	1,239,273	597,756	(150,000)	1,687,029
董事	仁典投資(股)公司	-	-	-	-	- (註 3)	-	1,100,000	-	14,035,619	15,135,619	1,316,057	-	16,451,676
	代表人：邵章榮	-	-	-	-	411,000	(171,000)	240,000	-	(240,000)	-	230,000	(141,000)	89,000
董事	力晶科技(股)公司	306,364,239	52,303,204 (註 1)	-	358,667,443	-	2,346,529,126	2,705,196,569	-	(1,879,504,929) (註 2)	825,691,640	71,794,730	(62,000,000)	835,486,370
	代表人：徐清祥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (註 4)	16,401	-	205,032
獨立董事	吳重雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	張嘉臨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林憲銘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	林本堅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	葉疏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
技術長	張守仁	-	-	-	-	498,301	-	498,301	-	426,498	924,799	280,412	(9,000)	1,196,211

註 1：該公司 106 年度盈餘轉增資發行新股計 52,303,204 股。
註 2：力晶科技(股)公司於 109 年度之減少股數 1,879,504,929 股，包含 7,101,000 股為該公司申請登錄興櫃，依相關法令提撥予券商及投資人保護中心等之股數。
註 3：仁典投資(股)公司係於 108 年 11 月 13 日就任，故僅揭露 108 年 11 月 13 日至 108 年 12 月 31 日之持股異動。
註 4：係於 110 年 6 月 9 日經力晶科技(股)公司改派為代表人，故僅揭露 110 年 6 月 9 日至 110 年 6 月 30 日之持股異動。

該公司及其子公司參與經營決策之董事及掌握生產技術與技術開發經理人等之股權增加行為，大多為參與現金增資所產生；而股權移轉行為，除母公司力晶科技(股)公司於 109 年度以該公司股票抵充應退還之減資股款配發予原股東案以及配合登錄興櫃提撥股票公推薦券商認購，以至於發生較為重大之股權移轉外，其餘股權移轉行為係基於個人理財所需，並未發現重大異常情形之股權移轉或轉讓之情事。

C.評估該等人員未來若未能繼續參與經營對發行公司財務業務之影響及其因應之措施

該公司及其子公司董事具備業務發展所需之產業或財務經驗，其主要透過董事會運作對該公司及其子公司經營策略及方向提供適當建議，並無單一董事或集團控制該公司及其子公司經營或日常運作。另該公司及其子公司長久以來累積半導體製造之相關技術經驗，其所擁有之技術並非由單一人所能完全掌握，加上該公司及其子公司已建立並落實研發管理制度及相關作業辦法，以及研發成果之保護，且研發人員任職時皆有簽訂保密同意書，該公司及其子公司亦十分重視研發人才的培訓，規劃多元的專業在職訓練，也提供完善的福利制度及獎酬辦法，以提升對公司的向心力及奠定穩固研發團隊之根基，故上述董事及員工離職時應不致對該公司及其子公司產生重大影響。

3.人力資源之營運風險

(1)員工總人數、離職人數、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資變動情形

單位：人；年；歲；%

年度 人數		107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
期初人員		6,599	6,931	6,878	7,174
新進人員		919	545	964	697
離職人員		563	534	644	544
資遣人員		6	53	9	6
退休人員		18	11	15	15
期末人數	直接人工	1,878	1,850	1,898	1,939
	間接人工	5,053	5,028	5,276	5,367
	合計	6,931	6,878	7,174	7,306
平均年資		8.98	9.62	9.88	10.20
平均年齡		36.72	37.77	38.07	38.59

資料來源：該公司及其子公司提供

(2)經理人、生產線員工及一般職員離職率之變化情形

單位：人；%

年度 人數	107 年度			108 年度			109 年度			110 年截至第三季		
	期末人數	離職人數	離職率(%)	期末人數	離職人數	離職率(%)	期末人數	離職人數	離職率(%)	期末人數	離職人數	離職率(%)
經理人	27	-	-	25	3	10.71	26	2	7.14	25	3	10.71
生產線員工	1,878	229	10.87	1,850	215	10.41	1,898	272	12.53	1,939	222	10.27
一般職員	5,026	358	6.65	5,003	380	7.06	5,250	394	6.98	5,342	340	5.98
合計	6,931	587	7.81	6,878	598	8.00	7,174	668	8.52	7,306	565	7.18

資料來源：該公司及其子公司提供

註：離職率=離職人數(含資遣及退休) / (期末人數+離職人數(含資遣及退休))

(3)員工人數及離職率變化情形之說明

該公司及其子公司最近三年度及截至 110 年 9 月底之員工人數分別為 6,931 人、6,878 人、7,174 人及 7,306 人，其人數變化主要係依該公司及其子公司整體之營業規模逐漸擴大而整體呈現人數增加趨勢。而員工平均年齡為 36.72 歲至 38.59 歲，顯示該公司及其子公司員工主要為青壯年人口，平均年資為 8.98 年至 10.20 年，離職員工主要以生產線作業人員及一般職員為主，惟整體人數及變動尚屬正常情形，故對該公司及其子公司營運應無重大風險。

該公司及其子公司最近三年度及截至 110 年 9 月底止之總離職人數分別為 587 人、598 人、668 人及 565 人，離職率分別為 7.81%、8.00%、8.52%及 7.18%，主要係生產線員工及一般職員，其員工離職原因主係因地域環境因素、個人生涯規劃、家庭環境及工作輪班因素而離職，惟該公司及其子公司皆已依其職責招募遞補適任員工，故對營運並無重大影響。此外，最近三年度及截至 110 年 9 月底止該公司及其子公司經理人離職人數分別為 0 人、3 人、2 人及 3 人，離職率甚低，離職原因主係因生涯規劃或退休，經理人於離職時已完成工作資料交接，且該公司及其子公司於短期內由內部或外部尋找具相關工作經驗之經理人接替其職位，故經理人之離職情形並未影響營運。

(4)員工學歷分析

單位：人；%

年度 項目	107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
	人數	比例(%)	人數	比例(%)	人數	比例(%)	人數	比例(%)
博士	42	0.61	45	0.65	49	0.68	49	0.67
碩士	2,079	30.00	2,098	30.50	2,279	31.77	2,346	32.11
大學(專)	3,767	54.34	3,703	53.85	3,806	53.05	3,877	53.07
高中(職)以下	1,043	15.05	1,032	15.00	1,040	14.50	1,034	14.15
合計	6,931	100	6,878	100.00	7,174	100.00	7,306	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司之員工學歷狀況自最近三年度及截至 110 年 9 月底，大學(專)以上學歷之員工占全體員工比例分別為 84.95%、85.00%、85.50%及 85.85%，大學(專)以上學歷之員工分佈任職各部門，負責銷售、採購、財務及研發等各業務，而高中(職)以下學歷之員工占該公司及其子公司員工比例分別為 15.05%、15.00%、14.50%及 14.15%，主係以生產部門之作業人員為主，負責相關機械操作等作業。隨著該公司及其子公司業績成長，生產規模及產能增加，該公司及其子公司因應不同工作性質之需求，持續招募各種學歷員工，並有效利用各種學歷員工之專業與技能，有助於強化企業管理，且高階幹部與研發人員以大學(專)以上學歷為主，故整體人員素質尚屬良好，應有助於增強該公司及其子公司經營實力與競爭力。

4.各主要產品之成本分析

(1)最近期及最近三個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素之比率變化對發行公司營運之風險

單位：新臺幣仟元；%

產品名稱	類別	107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
記憶體	原物料	2,169,838	12.57	2,221,035	12.86	1,671,810	10.21	1,098,313	9.75
	直接人工	614,930	3.56	550,596	3.19	478,853	2.92	344,209	3.05
	製造費用	14,472,000	83.87	14,498,123	83.95	14,223,810	86.87	9,826,215	87.20
	合計	17,256,768	100.00	17,269,754	100.00	16,374,473	100.00	11,268,737	100.00
邏輯	原物料	2,667,274	17.96	2,431,125	19.76	2,710,367	14.78	2,135,838	14.05
	直接人工	919,634	6.19	761,728	6.19	991,074	5.41	851,609	5.60
	製造費用	11,267,726	75.85	9,110,881	74.05	14,631,056	79.81	12,217,025	80.35
	合計	14,854,634	100.00	12,303,734	100.00	18,332,497	100.00	15,204,472	100.00
合計	原物料	4,837,112	15.06	4,652,160	15.73	4,382,177	12.63	3,234,151	12.22
	直接人工	1,534,564	4.78	1,312,324	4.44	1,469,927	4.24	1,195,818	4.52
	製造費用	25,739,726	80.16	23,609,004	79.83	28,854,866	83.13	22,043,240	83.26
	合計	32,111,402	100.00	29,573,488	100.00	34,706,970	100.00	26,473,209	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司之主要從事半導體晶圓代工服務、包裝元件及其他設計服務，晶圓代工主要可分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體晶圓代工業務，其主係依客戶需求而客製化之商品，因應客戶對邏輯及記憶體之需求量配置調整產線。由於半導體晶圓代工為資本密集產業需投入龐大機器設備，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季成本結構中，製造費用所占比例最高，分別占銷貨成本之 80.16%、79.83%、83.13%及 83.26%，其中製造費用 109 年度開始較其他年度明顯增加，主係因邏輯 IC 出貨暢旺產能利用率提升，故生產加工用之間接材料(光阻、氣體及化學品等)及生產設備折舊及維修所耗用之設備維修品隨之增加所致；其次為原料，占比分別為 15.06%、15.73%、12.63%及 12.22%，107~108 年度原料金額主係受到矽晶圓市場供需缺口嚴重，使矽晶圓價格上漲，於 109 年度原料價格回穩，故整體採購單價仍較低；而其成本結構中之直接人工所占比例最小，分別為 4.78%、4.44%、4.24%及 4.52%，整體占比亦較為穩定。

該公司及其子公司考量記憶體價格波動過大所產生之營運風險，於 108 年度開始調整產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，以降低記憶體產品價格變動對該公司及其子公司獲利之影響，並運用 12 吋產能與同業的 8 吋產能競爭，發揮成本優勢以提高毛利率。整體而言，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期之原料、人工及製造費用比重結構大致相同，其成本變化尚無重大異常之情事。

(2)符合「有價證券上市審查準則」第十六條規定之公司申請股票上市者，取得當(鄰)地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例(如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等)，以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，發行公司與地主之分配比率是否合理

該公司及其子公司非屬「有價證券上市審查準則」第十六條規定之建設公司，故不適用本項評估。

5.匯率變動情形

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止合併內外銷、內外購比率以分析匯率變動對發行公司營運之風險

內外銷金額及比例

單位：新台幣仟元；%

項目		107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
內銷		30,730,668	61.57	23,480,915	65.41	32,938,268	72.10	32,214,278	70.24
外銷	亞洲	8,265,107	16.56	5,114,172	14.25	9,367,146	20.50	10,242,094	22.33
	美洲	977,228	1.96	387,009	1.08	740,317	1.62	774,930	1.69
	歐洲	9,940,776	19.91	6,915,025	19.26	2,638,884	5.78	2,633,842	5.74
	小計	19,183,111	38.43	12,416,206	34.59	12,746,347	27.90	13,650,866	29.76
合計		49,913,779	100.00	35,897,121	100.00	45,684,615	100.00	45,865,144	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

單位：新臺幣仟元；%

項目		107 年度			108 年度			109 年度			110 年截至第三季		
		金額		%	金額		%	金額		%	金額		%
		原幣	本幣		原幣	本幣		原幣	本幣		原幣	本幣	
銷售	美元	1,642,033	49,331,990	98.83	1,159,512	35,861,526	99.90	1,544,468	45,683,615	100.00	1,633,874	45,863,144	100.00
	新臺幣	581,789	581,789	1.17	35,595	35,595	0.10	1,000	1,000	0.00	2,000	2,000	0.00
合計		—	49,913,779	100.00	—	35,897,121	100.00	—	45,684,615	100.00	—	45,865,144	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

內外購金額及比例

單位：新台幣仟元；%

項目		107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
內購	新臺幣	5,073,611	29.34	4,759,022	29.78	5,602,483	31.90	4,064,584	32.50
	美元	9,406,029	54.39	8,329,617	52.13	7,812,619	44.49	5,431,429	43.43
	歐元	1,925	0.01	4,574	0.03	431	0.00	1,556	0.01
	日幣	2,346,286	13.57	2,339,972	14.64	2,615,869	14.90	1,594,523	12.75
	小計	16,827,851	97.31	15,433,185	96.58	16,031,401	91.29	11,092,092	88.69
外購	新臺幣	411	0.01	617	0.01	1,518	0.01	1,282	0.01
	美元	299,865	1.73	356,723	2.23	1,270,528	7.24	1,253,350	10.02
	歐元	3,168	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	日幣	161,348	0.93	189,097	1.18	257,227	1.46	159,313	1.28
	小計	464,791	2.69	546,437	3.42	1,529,273	8.71	1,413,945	11.31
合計		17,292,642	100.00	15,979,622	100.00	17,560,674	100.00	12,506,037	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司於 107~109 年度及 110 年第三季之內銷占整體營業收入比重分別為 61.57%、65.41%、72.10%及 70.24%，外銷市場包括亞洲、美洲及歐洲等地區，不論內外銷交易主要計價幣別皆係美元，107~109 年度及 110 年第三季以美元計價之銷貨金額整體營業收入比重分別為 98.83%、99.90%、100.00%及 100.00%；在採購方面，該公司及其子公司以內購為主，107~109 年度及 110 年第三季內購比重分別為 97.31%、96.58%、91.29%及 88.69%，採購付款幣別亦以美元為主，107~109 年度及 110 年第三季以美元計價之進貨金額占總採購金額比率分別為 56.12%、54.36%、51.73%及 53.45%，其餘約 30%以新臺幣計價，約 15%以日圓支付。以美元計價之應收款項與應付款項相互沖抵可產生一定之自然避險效果，惟該公司及其子公司外幣收入大於外幣支出，無法互抵之美元應收款項在轉換成新臺幣時，因而產生匯兌損益，綜上評估，顯示該公司及其子公司匯兌損益主要受到美元匯率變動之影響。

匯兌損益占營收淨額及營業利益之比例

單位：新台幣仟元

項目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
兌換利益(損失)淨額(A)	166,282	(68,070)	(316,469)	(191,342)
營業收入淨額(B)	49,913,779	35,897,121	45,684,615	45,865,144
營業淨利(損失)(C)	8,886,597	(2,098,779)	5,744,244	12,551,292
占營業收入之比率(%)(A)/(B)	0.33%	(0.19%)	(0.69%)	(0.42%)
占營業淨利(損失)之比率(%)(A)/(C)	1.87%	(3.24%)	(5.51%)	(1.52%)

資料來源：該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第一季經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告

該公司及其子公司於 107~109 年度及 110 年第三季之兌換利益(損失)淨額分別為 166,282 仟元、(68,070)仟元、(316,469)仟元及(191,342)仟元，占營業收入之比率分別為 0.33%、(0.19%)、(0.69%)及(0.42%)，占營業淨利(損失)之比率則分別為 1.87%、(3.24%)、(5.51%)及(1.52%)；該公司及其子公司產生之兌換損益主要

係美元銷貨所產生。107 年度美國國內經濟增長強勁、聯準會持續升息，致美元平穩升值，進而產生淨兌換利益；108 年度受到美國聯準會三度降息之影響，致美元貶值，進而產生淨兌換損失；109 年度受到新冠肺炎疫情影響，對經濟產生巨大的衝擊，美國貨幣政策因此轉向寬鬆，且是無限量化寬鬆，致美元持續貶值，對於持有美元淨資產部位不利，因此持續產生兌換損失。惟該公司及其子公司進行衍生性工具交易，賣出美元遠期外匯以規避營業活動所暴露之匯率風險，以降低匯率波動之影響。

綜上所述，該公司及其子公司兌換損益之變化情形與匯率變動趨勢尚屬合理，各年度兌換(損)益占各年度合併營收淨額比率及營業利益影響有限，該公司及其子公司針對外幣資產負債匯率之風險管理除部分採自然避險外，並密切留意國際金融狀況，掌握最新之匯率市場變動，並請往來銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率走勢，並視實際外幣部位和資金狀況，於政策許可之範圍內，配合遠期外匯合約以規避匯率風險。

(2)因應匯率變動之具體措施

該公司及其子公司銷售皆以美元計價為主，採購約 50%以美元支付及約 15%以日圓支付因此產生外幣負債部位；另由於美元銷貨金額較進貨金額高，在外幣應收付款項互相沖抵後，仍有美元資產淨部位，故外幣匯率波動亦會產生匯兌損益，該公司及其子公司採取下列因應措施以降低匯率變動對其產生之影響：

A.匯率風險用外幣資產及負債自然避險為主，對於銷貨、進貨及資本支出均有一定比重以外幣計價，其整體對於匯率變動之影響可達到部分相互平衡之效果。

B.財務單位因應金融市場變化，隨時彙集相關資訊，判斷趨勢及風險評估，熟悉金融產品及法令規定，考量該公司及其子公司整體相關部位，編製操作策略方案，為規避風險之依據。

C.財務單位依授權權限，進行各項避險交易，就公司之已持有之外幣資產及負債部位，以及預期未來之外幣資產及負債部位，評估後與金融機構議定遠期外匯合約，以降低匯率波動風險對公司營運產生之影響。

D.業務單位向客戶報價及採購單位對外採購時，均會考慮匯率之波動幅度，適時反應調整價格，減緩匯率變化對公司獲利之衝擊。

E.該公司及其子公司訂有「取得或處分資產處理程序」，規範有關衍生性金融商品之交易原則與方針、風險管理措施等作業程序，並經股東會決議通過，作為從事衍生性金融商品相關作業之依據必要措施。

四、最近期及最近三個會計年度募集與發行有價證券籌資效益

請參閱本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形」之說明。

參、就發行人下列業務財務狀況蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、業務狀況

(一)最近期及最近三個會計年度財務報告主要銷售對象及供應商（年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者）之變化分析

1.最近期及最近三個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例，主要銷售對象變化情形之原因並分析是否合理，是否有銷售集中之風險，並簡述發行人之銷售政策

(1)最近期及最近三個會計年度主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位：新台幣仟元；%

	107 年度				108 年度				109 年度				110 年截至第三季			
	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係
1	G 公司	9,870,890	19.78	無	G 公司	6,467,776	18.02	無	H 公司	7,721,858	16.90	無	H 公司	5,130,749	11.19	無
2	H 公司	6,443,299	12.91	無	H 公司	5,180,476	14.43	無	A 公司	4,468,525	9.78	無	A 公司	4,493,474	9.80	無
3	A 公司	3,336,612	6.68	無	A 公司	3,118,477	8.69	無	G 公司	2,530,010	5.54	無	J 公司	2,744,732	5.98	無
4	B 公司	3,213,770	6.44	無	K 公司	1,858,177	5.18	無	F 公司	1,996,878	4.37	無	智豐	2,606,746	5.68	註 1
5	C 公司	3,019,619	6.05	無	C 公司	1,747,580	4.87	無	C 公司	1,985,010	4.35	無	G 公司	2,523,011	5.50	無
6	智豐	2,662,231	5.33	註 1	I 公司	1,621,662	4.52	無	D 公司	1,862,556	4.08	無	K 公司	1,976,549	4.31	無
7	I 公司	2,298,345	4.60	無	智豐	1,605,063	4.47	註 1	K 公司	1,791,038	3.92	無	D 公司	1,749,760	3.82	無
8	J 公司	1,810,451	3.63	註 2	D 公司	1,426,453	3.97	無	I 公司	1,646,123	3.60	無	F 公司	1,746,086	3.81	無
9	K 公司	1,804,855	3.62	無	E 公司	1,274,482	3.55	無	J 公司	1,489,438	3.26	無	C 公司	1,662,512	3.62	無
10	D 公司	1,605,728	3.22	無	J 公司	1,251,172	3.49	無	E 公司	1,475,836	3.23	無	I 公司	1,650,630	3.60	無
	小計	36,065,800	72.26		小計	25,551,318	71.19		小計	26,967,272	59.03		小計	26,284,249	57.31	
	其他	13,847,979	27.74		其他	10,345,803	28.81		其他	18,717,343	40.97		其他	19,580,895	42.69	
	合計	49,913,779	100.00		合計	35,897,121	100.00		合計	45,684,615	100.00		合計	45,865,144	100.00	

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：智豐係為實質關係人。

註 2：J 公司係為實質關係人，惟 107 年 9 月 4 日董監改選後為非關係人。

(2)最近期及最近三個會計年度主要銷售對象變化情形之原因分析

A.邏輯暨特殊應用產品晶圓代工

(A)A 公司

該公司及其子公司與 A 公司交易始於 97 年，主要銷售之產品為大小尺寸之 LCD 驅動 IC。107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 3,336,612 仟元、3,118,477 仟元、4,468,525 仟元及 4,493,474 仟元，銷售比重分別為 6.68%、8.69%、9.78%及 9.80%，108 年度邏輯市況較差，致對其銷貨金額相較前一年度微幅減少，109 年度增加主係新冠肺炎疫情延燒帶動居家辦公、遠距教學、宅經濟等消費行為，A 公司受惠於筆電、平板電腦、電競顯示器與手機等相關終端需求增加，致面板驅動 IC 出貨暢旺。110 年截至第三季度銷售金額較去年同期增加，主係延續 109 年度態勢出貨持續暢旺，且晶圓代工整體產能滿載且終端需求增加，帶動市場價格上漲所致。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(B)B 公司

該公司及其子公司與 B 公司交易始於 103 年，主要銷售之產品為驅動 IC。107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 3,213,770 仟元、1,181,644 仟元、373,456 仟元及 341,015 仟元，銷售比重分別為 6.44%、3.29%、0.82%及 0.74%，銷售金額呈逐年遞減之趨勢，主係 B 公司於 108 年度之後僅出既有產品，後續尚無新產品銜接，對其銷貨收入逐漸減少，致 108 年度之後遂退出前十大之列。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(C)C 公司

該公司及其子公司與 C 公司之交易始於 97 年，主要銷售產品為 LCD 驅動 IC。107~109 年度及 110 年截至第三季對 C 公司銷售金額分別為 3,019,619 仟元、1,747,580 仟元、1,985,010 仟元及 1,662,512 仟元，銷售比重分別為 6.05%、4.87%、4.35%及 3.62%，最近三年度均名列該公司及其子公司第五大銷售客戶，107 年銷售金額較高主要係新產品線大尺寸面板驅動 IC 打入新客戶，陸續出貨放量所致。108 年度因邏輯市況較差，銷售金額隨之減少。109 年度雖於下半年度市況已逐漸回溫，惟客戶投片較慢，致銷售金額微幅增加。110 年截至第三季受惠於終端市場需求拉貨，銷售金額相較去年同期增加，惟因該公司及其子公司對其他銷售客戶銷售金額及比重增加，致排名略降至第九大銷售客戶。其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(D)D 公司

該公司及其子公司與 D 公司交易始於 104 年，主要銷售之產品為手機及 RFID 系統 IC 晶片，107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 1,605,728 仟元、1,426,453 仟元、1,862,556 仟元及 1,749,760 仟元，銷售比重分別為 3.22%、3.97%、4.08%及 3.82%。108 年度對其銷貨金額微幅降低，主要係智慧型手機需求放緩所致。109 年度及 110 年截至第三季主係 RFID 系統 IC 晶片受惠於大宗消費電子商品應用復甦，故銷售金額相較去年同期隨之增加。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(E)E 公司

該公司及其子公司與 E 公司交易始於 93 年，主要銷售之產品為 CMOS 影像感測器之晶片，107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 1,127,189 仟元、1,274,482 仟元、1,475,836 仟元及 1,337,410 仟元，銷售比重分別為 2.26%、3.55%、3.23%及 2.92%。主係因 E 公司之 CMOS 影像感測器已經切入美國及中國大陸等各大安防大廠供應鏈，因此受惠於智慧安防需求成長效應，中低畫素影像感測器出貨暢旺，致最近三年度及 110 年截至第三季度呈穩定成長之趨勢。

(F)F 公司

該公司及其子公司與 F 公司交易始於 101 年，主要銷售之產品為 LCD 驅動 IC 及 TDDI(觸控暨驅動整合晶片)，107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 777,838 仟元、113,276 仟元、1,996,878 仟元及 1,746,086 仟元，銷售比重分別為 1.56%、0.32%、4.37%及 3.81%。108 年度銷售金額較去年同期大幅下降，主要係因該公司及其子公司新舊產品尚未銜接之空窗期所致。而 109 年度銷售金額隨之大幅增加，主要係新產品於 108 年度第四季完成開發，並於該年底已獲得客戶採用，且 109 年度新產品隨智慧手機市場買氣增溫及 5G 滲透率提升發酵並出貨放量所致，躍升為第四大銷貨客戶。110 年截至第三季承 109 年下半年產業需求持續增溫，驅動 IC、觸控 IC 等產品出貨維持高檔態勢，故 110 年截至第三季銷售金額相較去年同期成長，名列該公司及其子公司第八大銷售客戶。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

B.記憶體產品晶圓代工

(A)G 公司

該公司及其子公司與 G 公司交易始於 95 年，主要銷售產品為記憶體，以標準型 DRAM 產品為主，該公司及其子公司自與 G 公司交易以來已久，均維持良好關係，品質獲得客戶信賴，最近三年度及 110 年截至第三季皆為該公司及其子公司前十大銷售客戶之列。107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 9,870,890 仟元、6,467,776 仟元、2,530,010 仟元及 2,523,011

仟元，銷售比重分別為 19.78%、18.02%、5.54%及 5.50%，107 及 108 年度為該公司及其子公司銷售第一大銷售客戶，108 年度較 107 年度下降，主係 108 年度因記憶體市場成長趨緩、終端需求降溫等因素，出現供過於求的狀況，致標準型記憶體平均銷售價格下跌，109 年度記憶體市況雖於第四季谷底回升，惟標準型 DRAM 平均報價仍處低檔，且終端需求萎縮致拉貨數量減少，遂退至第三大銷售客戶。110 年截至第三季銷售金額相較去年同期增加，主係標準型 DRAM 受惠於新冠肺炎疫情持續終端需求持續增溫所致。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(B)H 公司

該公司及其子公司與 H 公司之交易始於 90 年，主要銷售產品為記憶體產品晶圓代工，產品包含利基型 DRAM、NAND Flash 及 NOR Flash，以利基型 DRAM 為大宗。107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 6,443,299 仟元、5,180,476 仟元、7,721,858 仟元及 5,130,749 仟元，銷售比重分別為 12.91%、14.43%、16.90%及 11.19%。108 年度下降主要係記憶體市場終端需求不振及平均售價跌價致 H 公司營收下滑，向該公司及其子公司採購金額隨之下降。109 年度相較去年同期金額大幅增加，主係 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，且由於三大記憶體廠商(三星、SK 海力士、美光)在 109 年下半年將舊製程利基型 DRAM 產能移轉至 CMOS 影像感測器製程後，使得利基型 DRAM 市場供給產生短缺，H 公司受惠缺貨效應而出貨暢旺。110 年截至第三季度銷售金額 5,130,749 仟元，相較去年同期 6,053,878 仟元減少 15.25%，主係該公司及其子公司產能持續滿載，110 年截至第三季產能供貨數量減少所致。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(C)智豐科技股份有限公司(以下簡稱：智豐)

智豐成立於 91 年，位於台灣台北市，主要經營業務為電子零組件之銷售業務。

該公司及其子公司與智豐交易始於 91 年，主要銷售產品為記憶體，以標準型 DRAM 為主。107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 2,662,231 仟元、1,605,063 仟元、1,472,901 仟元及 2,606,746 仟元，銷售比重分別為 5.33%、4.47%、3.22%及 5.68%。主係 108 年度因記憶體市場成長趨緩、終端需求降溫等因素，出現供過於求的狀況，致平均銷售價格下跌，109 年度記憶體市況雖於第四季谷底回升，惟標準體記憶體平均報價仍處低檔，且終端需求萎縮致拉貨數量減少，遂退出前十大之列。110 年截至第三季度受惠於標準型 DRAM 因新冠肺炎疫情持續推動終端需求暢旺，銷售價格上漲故躍升為第四大銷售客戶。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(D)I 公司

該公司及其子公司與 I 公司交易始於 88 年，主要銷售產品為記憶體，以利基型 DRAM 為主，107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 2,298,345 仟元、1,621,662 仟元、1,646,123 仟元及 1,650,630 仟元，銷售比重分別為 4.60%、4.52%、3.60%及 3.60%。108 年度下降主要係記憶體市場終端需求不振及平均售價跌價，致該公司及其子公司銷售予 I 公司金額隨之減少，109 年度雖因第四季利基型記憶體市場回溫，終端需求釋出，惟因 I 公司本身銷售產品品項較少，故銷售金額僅呈小幅成長。110 年截至第三季相較去年同期增加，主係受惠於記憶體大廠在 109 年下半年持續進行產能調整，利基型 DRAM 供貨量減少，已由供需平衡轉為供給短缺，致利基型記憶體需求及價格均呈增加。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(E)J 公司

該公司及其子公司與 J 公司交易始於 100 年，主要銷售產品為記憶體，以利基型 DRAM 為主，107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 1,810,451 仟元、1,251,172 仟元、1,489,438 仟元及 2,744,732 仟元，銷售比重分別為 3.63%、3.49%、3.26%及 5.98%。108 年度下降主要係記憶體市場終端需求不振及平均售價跌價，致對 J 公司銷售金額隨之減少，109 年度及 110 年截至第三季相較去年同期增加，主係因 109 年第四季記憶體市場回溫，終端需求釋出，故銷售予 J 公司金額隨之成長。綜上所述，其變化情形尚屬合理，應無重大異常之情事。

(F)K 公司

該公司及其子公司與 K 公司交易始於 102 年，主要銷售產品為記憶體，以利基型 DRAM 為主。107~109 年度及 110 年截至第三季對其銷售金額分別為 1,804,855 仟元、1,858,177 仟元、1,791,038 仟元及 1,976,549 仟元，銷售比重分別為 3.62%、5.18%、3.92%及 4.31%。雙方合作以來維持良好關係，品質獲得客戶信賴，各年度銷售金額均維持穩定，且均名列該公司及其子公司之前十大銷售客戶，其變化情形尚屬合理。

(3)是否有銷貨集中之風險

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季對前十大銷售客戶之銷售金額分別為 36,065,800 仟元、25,551,318 仟元、26,967,272 仟元及 26,284,249 仟元，銷售比重分別為 72.26%、71.19%、59.03%及 57.31%，且各年度對第一大銷售客戶之銷售比重分別為 19.78%、18.02%、16.90%及 11.19%，並未有單一銷售對象之銷售比重逾 30%以上之銷售客戶，且第一大銷售客戶之銷售比重呈逐年降低之趨勢，整體而言，該公司及其子公司尚無銷貨集中風險之虞。

(4)發行人之銷售政策

該公司及其子公司主要營業項目係為晶圓代工產品之研發、生產及銷售，近年來成功從 DRAM 轉型至晶圓代工產業，係台灣主要針對客製化邏輯晶片與先進記憶體之晶圓代工服務為主軸的公司：記憶體產品，分別有 DRAM、NAND Flash 及 NOR Flash 等產品；特殊邏輯產品，則有顯示器驅動 IC、影像感測 IC、電源管理 IC 及嵌入式邏輯 IC 等不同應用之產品。該公司及其子公司基於記憶體技術的優勢基礎，同時亦切入邏輯晶片的市場，且達到記憶體及邏輯晶片彈性調配產能之優勢，未來更將積極朝記憶體與邏輯晶片的異質整合發展趨勢。茲將該公司及其子公司之銷售政策列示如下：

A.為全台主要兼具記憶體及邏輯製程技術之公司，且為全球唯二擁有兩座 12 吋鋁製程之晶圓廠，開發大規模之高性價比產品，提高銷售產品之競爭力。

B.啟動 Open Foundry 策略，吸引策略夥伴分攤晶圓代工所需之龐大資本支出，除更增添該公司及其子公司本身營業資金調度之靈活度外，更贏得許多國內外知名廠商長期穩定合作關係，奠定該公司及其子公司長期發展之穩定基礎。

C.具備自主研發的能力，積極快速提供符合客戶需求之客製化產品來確保產品之市場競爭力，透過與客戶緊密合作，以自主開發(Platform)、技術導入共同開發(Port in)、技術移轉(Technology Transfer)三大方向協助銷售客戶快速導入量產。

D.針對品質系統亦遵循 ISO 9001、IATF 16949、IECQ QC 080000、ISO 14001、ISO45001 等國際標準，符合全球客戶出貨法規，品質穩定，深受國內外大廠信賴。

2.最近期及最近三個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額，並分析主要供應商之變化情形

(1)最近期及最近三個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新臺幣仟元；%

排名	107 年度				108 年度				109 年度				110 年截至第三季			
	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係	公司名稱	金額	比例	與發行人關係
1	甲公司	2,522,517	14.59	無	甲公司	2,025,643	12.68	無	甲公司	1,588,215	9.04	無	丙公司	1,195,952	9.56	無
2	乙公司	1,644,860	9.51	無	丙公司	1,468,660	9.19	無	乙公司	1,557,851	8.87	無	甲公司	1,125,199	9.00	無
3	丙公司	1,509,364	8.73	無	乙公司	1,331,234	8.33	無	丙公司	1,525,403	8.69	無	乙公司	1,108,721	8.87	無
4	丁公司	847,321	4.90	無	丁公司	853,031	5.34	無	丑公司	925,343	5.27	無	丁公司	632,808	5.06	無
5	戊公司	719,465	4.16	無	壬公司	676,556	4.23	無	丁公司	865,756	4.93	無	卯公司	531,593	4.25	無
6	己公司	611,686	3.54	無	戊公司	674,599	4.22	無	己公司	600,637	3.42	無	丑公司	489,615	3.92	無
7	庚公司	599,210	3.46	無	己公司	583,432	3.65	無	辛公司	527,429	3.00	無	己公司	450,164	3.60	無
8	辛公司	560,377	3.24	無	辛公司	522,185	3.27	無	寅公司	459,018	2.61	無	寅公司	416,069	3.33	無
9	壬公司	532,598	3.08	無	庚公司	343,116	2.15	無	卯公司	455,945	2.60	無	辛公司	311,615	2.49	無
10	癸公司	333,379	1.93	無	癸公司	335,651	2.10	無	辰公司	385,398	2.20	無	癸公司	266,491	2.13	無
	小計	9,880,777	57.14		小計	8,814,107	55.16		小計	8,890,995	50.63		小計	6,528,227	52.21	
	其他	7,411,865	42.86		其他	7,165,515	44.84		其他	8,669,679	49.37		其他	5,977,810	47.79	
	合計	17,292,642	100.00		合計	15,979,622	100.00		合計	17,560,674	100.00		合計	12,506,037	100.00	

資料來源：該公司及其子公司提供。

(2)發行公司最近期及最近三個會計年度主要供應商之變化情形

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務、包裝元件及其他設計服務，晶圓代工主要可分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體晶圓代工業務，故該公司及其子公司主要進貨項目為矽晶圓與零配件，其他進貨項目為光阻、各類化學品等。107~109 年度及 110 年截至第三季之前十大進貨金額分別為 9,880,777 仟元、8,814,107 仟元、8,890,995 仟元及 6,528,227 仟元，占各期進貨淨額比重分別為 57.14%、55.16%、50.63%及 52.21%。茲就該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季主要供應商之變化情形分析說明如下：

A.甲公司

該公司及其子公司自 101 年開始與甲公司交易往來，主要向甲公司採購 8 吋及 12 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 2,522,517 仟元、2,025,643 仟元、1,588,215 仟元及 1,125,199 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 14.59%、12.68%、9.04%及 9.00%，供應商排名 107~109 年度皆為第一大供應商，110 年截至第三季則為第二大供應商，主係雙方長期維持穩定合作關係，於品質、產量及交期上較能配合該公司及其子公司需求，而進貨淨額及比率逐年降低主係該公司及其子公司積極分散供貨來源，開發其他合格供應商，加上矽晶圓採購價格於 109 年開始下降，故對其進貨淨額及比率亦隨之降低。

B.乙公司

該公司及其子公司自 93 年開始與乙公司交易往來，主要向乙公司採購 8 吋及 12 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 1,644,860 仟元、1,331,234 仟元、1,557,851 仟元及 1,108,721 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 9.51%、8.33%、8.87%及 8.87%，供應商排名 107~109 年度及 110 年截至第三季分別占第二大、第三大、第二大及第三大，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係，主係乙公司於品質、產量及交期上較能配合該公司及其子公司需求，整體而言，對其採購金額及比率尚無重大異常情形。

C.丙公司

該公司及其子公司自 97 年開始與丙公司交易往來，主要向丙公司購買零配件及石英等矽晶圓加工所需耗材，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 1,509,364 仟元、1,468,660 仟元、1,525,403 仟元及 1,195,952 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 8.73%、9.19%、8.69%及 9.56%，供應商排名 107~109 年度及 110 年截至第三季分別占第三大、第二大、第三大及第一大，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係，主係該公司及其子公司生產設備向其購買，故於生產設備維護時，會優先採購原廠提供的設備維修品，加上丙公司提供之設備維修品於品質方面也優於其他供應商，整體而言，對其採購金額及比率尚無重大異常情形。

D.丁公司

該公司及其子公司自 95 年開始與丁公司交易往來，主要向丁公司採購半導體材料，包含光阻劑、石英、IC 製程用化學品與特殊氣體等用於晶圓加工所需，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 847,321 仟元、853,031 仟元、865,756 仟元及 632,808 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 4.90%、5.34%、4.93%及 5.06%，供應商排名 107~108 年度及 110 年截至第三季為第四大供應商，109 年度為第五大供應商，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係，主係丁公司於早期便取得該公司及其子公司合格供應商資格，提供之半導體材料主要為光阻劑，因晶圓代工大多為客製化製程，各製程對於光罩及光阻劑需求皆有其特定性，故整體變化會隨使用該光阻劑之產品變動銷量變動，若銷貨訂單及供貨來源品質無重大變化時，對其採購金額及比率便會維持穩定，整體無重大異常情形。

E.戊公司

該公司及其子公司自 88 年開始與戊公司交易往來，主要向戊公司購買生產設備維修所耗用之設備維修品，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 719,465 仟元、674,599 仟元、34,598 仟元及 21,483 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 4.16%、4.22%、0.20%及 0.17%，供應商排名 107~108 年度分別占第五大及第六大，採購金額逐漸降低主要係戊公司為丑公司之代理商，109 年開始原廠丑公司策略調整，將機台及零配件業務轉為原廠直售，故於 109 年度退出前十大供應商之列。

F.己公司

該公司及其子公司自 85 年開始與己公司交易往來，向己公司購買 8 吋矽晶圓、光阻劑、石英、氣體、化學品等，並以光阻劑為主要採購項目，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 611,686 仟元、583,432 仟元、600,637 仟元及 450,164 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.54%、3.65%、3.42%及 3.60%，供應商排名 107~109 年度及 110 年截至第三季分別占第六大、第七大、第六大及第七大，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係，係因己公司主要代理庚公司之產品，其光阻劑之品質穩定且能配合公司交期，因晶圓代工大多為客製化製程，各製程對於光罩及光阻劑需求皆有其特定性，故整體變化會隨使用該光阻劑之產品變動銷量變動，若銷貨訂單及供貨來源品質無重大變化時，對其採購金額及比率便會維持穩定，整體而言，對其採購金額及比率穩定尚無重大異常情形。

G.庚公司

該公司及其子公司自 90 年開始與庚公司交易往來，主要向庚公司購買 8 吋及 12 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 599,210 仟元、343,116 仟元、118,056 仟元及 45,181 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.46%、2.15%、0.67%及 0.36%，供應商排名 107~109 年度分

別為第七大及第九大供應商，對其進貨淨額及比率逐年下降係因庚公司提供之矽晶圓報價相對其他供應商逐漸較不具價格優勢，故自 109 年度起退出前十大供應商之列。

H.辛公司

該公司及其子公司自 97 年開始與辛公司交易往來，主要向辛公司購買零配件及石英等矽晶圓加工所需耗材，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 560,377 仟元、522,185 仟元、527,429 仟元及 311,615 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.24%、3.27%、3.00%及 2.49%，供應商排名 107~108 年度為第八大供應商，109 年度及 110 年截至第三季則分別為第七大及第九大供應商，對其進貨淨額及比例維持穩定合作關係，整體而言尚無重大異常情形。

I.壬公司

該公司及其子公司自 97 年開始與壬公司交易往來，主要向壬公司購買 8 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 532,598 仟元、676,556 仟元、173,381 仟元及 0 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 3.08%、4.23%、0.99%及 0.00%，供應商排名 107~108 年度分別占第九大及第五大，109 年開始係因將 8 吋矽晶圓銷售業務轉給其子公司卯公司，故進貨淨額及比率逐漸降低，致壬公司退出前十大供應商之列。

J.癸公司

該公司及其子公司自 88 年開始與癸公司交易往來，主要向癸公司購買光阻劑，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 333,379 仟元、335,651 仟元、357,262 仟元及 266,491 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.93%、2.10%、2.03%及 2.13%，供應商排名 107~108 年度及 110 年截至第三季皆為第十大，而 109 年度採購金額仍維持穩定，惟採購總進貨淨額上升，故退出前十大供應商之列，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係。

K.丑公司

該公司及其子公司自 108 年開始與丑公司交易往來，主要向丑公司購買晶圓代工所需之零配件，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 0 仟元、72,307 仟元、925,343 仟元及 489,615 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、0.45%、5.27%及 3.92%，109 年度及 110 年截至第三季進貨淨額及比例大幅提升，主係戊公司為丑公司之代理商，109 年開始因原廠丑公司進行策略調整，將機台及零配件業務轉為原廠直售，使丑公司於 109 年度及 110 年截至第三季分別成為第四大及第六大供應商。

L.寅公司

該公司及其子公司自 105 年開始與寅公司交易往來，主要向寅公司購買 8 吋及 12 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 107,635 仟元、150,431 仟元、459,018 仟元及 416,069 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0.62%、0.94%、2.61%及 3.33%，對其進貨淨額及比率逐年提高，主係因 109 年開始因銷貨端產品組合改變，使用寅公司供給之矽晶圓加工產品銷量提高，故於 109 年度開始進入前十大供應商之列。

M.卯公司

該公司及其子公司自 109 年開始與卯公司交易往來，主要向卯公司購買 8 吋矽晶圓，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 0 仟元、0 仟元、455,945 仟元及 531,593 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 0%、0%、2.60%及 4.25%，109 年係因母公司壬公司將 8 吋矽晶圓銷售業務轉給卯公司，故向其開始採購 8 吋矽晶圓，故向卯公司進貨淨額及比例逐漸增加，於 109 年度及 110 年截至第三季分別為第九大及第五大供應商。

N.辰公司

該公司及其子公司自 93 年開始與辰公司交易往來，主要向辰公司購買矽晶圓加工所需之研磨片及研磨液，107~109 年度及 110 年截至第三季對其進貨淨額分別為 317,734 仟元、285,378 仟元、385,398 仟元及 264,210 仟元，其占各年度進貨淨額之比率分別為 1.84%、1.79%、2.20%及 2.11%，110 年截至第三季採購金額仍維持穩定，惟採購總進貨淨額上升，故退出前十大供應商之列，進貨淨額及比率長期維持穩定合作關係。

(3)供貨來源穩定性之評估

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季對前十大供應商之進貨淨額比例分別為 57.14%、55.16%、50.63%及 52.21%；107~109 年度及 110 年截至第三季來自第一大供應商之比重分別為 14.59%、12.68%、9.04%及 9.56%，顯見其供應商尚屬分散。其中矽晶圓均有二家以上之供應商，而零配件及其他生產原料，如：光阻、氣體、化學品及消耗材料等，品項分散且原物料種類繁多，亦無進貨集中之情形，故評估該公司及其子公司應無進貨集中之風險。該公司及其子公司主要原料為矽晶圓及零配件，其供應商多為業界知名廠商，且上游原料供應商眾多，是以採購單位進行原料採購會考量市場供需、品質狀況、供應商產能及產品組合等，決定最佳採購量。為靈活調整採購來源及採購量，且分散進貨過度集中風險，主要原料採購均維持二家以上之供應商，並皆維持長期往來之合作關係，截至評估報告出具日止，並無供貨短缺或中斷情形發生。

(二)最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、母子公司備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告應收款項變動之合理性、備抵損失提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

該公司及其子公司合併報表編製主體包含該公司本身暨其轉投資公司 Global Powertec Co., Ltd.(以下簡稱 Global Powertec)、PowerMemory Inc.(以下簡稱 Power Memory)及 Maxram Inc.(以下簡稱 Maxram)。其中該公司統籌集團經營策略，主要負責晶圓代工業務，包含記憶體及邏輯 IC 之研發、生產及銷售，而集團子公司依其定位各有不同，Global Powertec 屬投資控股公司，並無實質營運；PowerMemory 及 Maxram 則分別負責 Flash 及 DRAM 製程相關設計及研發，故合併應收款項主要僅來自於該公司本身。以下僅就該公司最近期及最近二個會計年度所出具之合併財務報告進行應收款項變動之合理性、備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估。

(1)應收款項變動之合理性

單位：新臺幣仟元

項目＼期間		108 年度	109 年度	110 年截至第三季
營業收入淨額		35,897,121	45,684,615	45,865,144
應收款項總額	應收票據	—	—	—
	應收帳款	5,344,970	5,981,210	8,766,864
	應收帳款-關係人	49,914	253,494	307,058
	小計	5,394,884	6,234,704	9,073,922
備抵損失提列數		—	—	—
應收款項淨額		5,394,884	6,234,704	9,073,922
應收款項週轉率(次)		6.10	7.86	7.99
應收款項收現天數(天)		60	47	46
授信條件		考量個別客戶資本額、營運規模、財務狀況及過往交易情形、收款記錄等而給予不同之授信條件，收款條件主要為月結 30 天～60 天。		

資料來源：各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季之營業收入淨額分別為 35,897,121 仟元、45,684,615 仟元及 45,865,144 仟元，期末應收款項總額分別為 5,394,884 仟元、6,234,704 仟元及 9,073,922 仟元。109 年底應收款項總額較 108 年底增加 839,820 仟元，成長幅度為 15.57%，主係邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，致期末應收款項亦隨之增加。110 年截至第三季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並

帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，營業收入相較去年同期增加 35.65%，使應收帳款總額較 109 年底增加 45.54%。整體而言，該公司及其子公司最近二年度合併應收款項變化情形主係隨合併營業收入變化而變動，尚無重大異常。

在應收款項週轉率方面，該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季應收款項週轉率分別為 6.10 次、7.86 次及 7.99 次，應收款項收現天數分別為 60 天、47 天及 46 天，介於正常授信期間內，尚無重大異常之情事。109 年度應收款項週轉率較 108 年度上升，主係邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫使得營業收入增加，且增加之幅度較 109 年平均應收款項增加幅度大，致應收款項收現天數下降。110 年截至第三季承 109 年下半年出貨暢旺態勢，應收款項週轉率與 109 年度差異不大。整體而言，該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季之應收款項收現天數落在 46~60 天，與主要授信條件相當，尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近二個會計年度之應收款項總額變動及應收款項週轉率變化情形應屬合理，尚無重大異常之情事。

(2)備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估

A.備抵損失提列政策

該公司及其子公司採用 IFRS 9 之公報規定，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，係按代表客戶依據信用條件支付所有到期金額能力之共同信用風險特性，並已納入前瞻性之資訊，包括總體經濟及所屬半導體相關產業資訊。並使用準備矩陣提列預期信用損失，計算出過去期間歷史違約率，及考量前瞻性調整後，依應收款項逾期天數分組進行準備矩陣計算，據以評估備抵損失應提列之金額。此外，該公司及其子公司亦考量個別客戶違約紀錄與現時財務狀況，若有相當資訊足以確認個別客戶之應收款項未來收回可能性不大者，將個別提列備抵損失。

帳齡		平均推估損失率		
		108 年度適用	109 年度適用	110 年截至第三季適用
未逾期		0%	0%	0%
逾期	1-30 天	0%	0%	0%
	31-60 天	0%	0%	0%
	61-90 天	0%	0%	0%
	91-120 天	0%	0%	0%
	121-150 天	0%	0%	0%
	151-180 天	0%	0%	0%
	超過 180 天以上	0%	0%	0%

資料來源：該公司及其子公司提供。

B.備抵損失提列之適足性

單位：新臺幣仟元

項目	108 年底	109 年底	110 年 截至第三季
應收款項總額(B)	5,394,884	6,234,704	9,073,922
備抵損失金額(A)	—	—	—
備抵損失提列比率(A)/(B)	0%	0%	0%

資料來源：各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司依據客戶過往交易情形、銷售能力、財務及經營狀況，綜合考量後定交易條件，定期檢視逾期應收款項進行催收，以防範異常帳款之發生，降低未來帳款無法回收可能性；另依據應收款項帳齡及過去對客戶之收款經驗，訂定應收帳款/應收票據減損提列細則，並個別檢視應收款項客戶提列備抵損失金額。該公司及其子公司 108~109 年底及 110 年 9 月底依據收款情形評估並無提列備抵損失金額，經檢視該公司及其子公司之主要銷售客戶多為國內外知名大廠，營運規模、財務狀況及長期往來信用良好，帳款品質穩定，且最近二年度及 110 年截至第三季並無實際發生備抵損失。整體而言，該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季提列之備抵損失金額尚依所訂之政策執行，應已涵蓋帳款未能收回之風險，經評估其備抵損失適足性尚無疑慮。

C.應收款項收回可能性評估

該公司最近期經會計師核閱之財務報告所列第三季底，與刊印日前一個月所指九月底為同一時點，故不予分析。茲就上半年度截至九月底之應收款項收回情形，分析如下：

單位：新臺幣仟元

項目	110 年 6 月底	截至 110 年 9 月底之收回情形			
		收回金額	收回比率 (%)	未收回金額	未收回比率 (%)
應收帳款	8,393,551	8,393,551	100	-	-

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司 110 年 6 月底之應收帳款及應收帳款關係人分別為 8,062,800 仟元及 330,751 仟元，截至 110 年 9 月底止，應收款項業已全數收回。此外，108~109 年度及 110 年截至三季並未有實際發生壞帳之情形，故應收款項收回應屬無虞。整體而言，該公司及其子公司應收款項收回情形尚屬良好，並無重大無法收回疑慮之情事。

(3)與同業比較

單位：新臺幣仟元；次；天；%

項目	年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
營業收入	力積電	35,897,121	45,684,615	28,573,900
	聯電	148,201,641	176,820,914	註
	世界	28,286,072	33,131,202	註
	華邦電	48,771,434	60,683,171	註
應收款項總額	力積電	5,394,884	6,234,704	9,073,922
	聯電	26,426,336	27,479,357	註
	世界	4,968,945	5,734,253	註
	華邦電	6,279,259	10,051,897	註
備抵損失帳列金額	力積電	—	—	—
	聯電	697,590	206,084	註
	世界	731	731	註
	華邦電	148,353	266,759	註
應收款項淨額	力積電	5,394,884	6,234,704	9,073,922
	聯電	25,728,746	27,273,273	註
	世界	4,968,214	5,733,522	註
	華邦電	6,130,906	9,785,138	註
應收款項週轉率(次)	力積電	6.10	7.86	7.99
	聯電	5.89	6.56	註
	世界	5.29	6.19	註
	華邦電	7.53	7.43	註
應收款項週轉天數(天)	力積電	60	47	46
	聯電	62	56	註
	世界	69	59	註
	華邦電	49	50	註
備抵損失占應收帳款之比重(%)	力積電	—	—	—
	聯電	2.64	0.75	註
	世界	0.01	0.01	註
	華邦電	2.36	2.65	註

資料來源：各期間經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。
註：截至刊印日止，同業尚未公告第三季財務報告。

該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季之應收款項週轉率分別為 6.10 次、7.86 次及 7.99 次，應收款項收現天數分別為 60 天、47 天及 46 天，該公司及其子公司最近二年度及 110 年截至第三季合併應收款項變化情形主係隨合併營業收入變化而變動。與採樣同業相較，該公司及其子公司 109 年度應收款項週轉率優於採樣同業，108 年度及 110 年截至第三季應收款項週轉率及收現天數均介於採樣同業之間，採樣同業間應收款項週轉情形差異主係因各公司之營

運規模、收款政策及客戶組成不同所致，尚無重大異常之情事。

在備抵損失提列金額方面，該公司及其子公司 108~109 年底及 110 年 9 月底依據收款情形評估並無提列備抵損失金額。與採樣同業相較，該公司及其子公司因無提列備抵損失金額，故提列比率均低於所有採樣同業，主係因該公司及其子公司依照公司政策執行收款，於 108~109 年度及 110 年截至第三季並無發生實際呆帳損失之情形，且期後實際收回情形尚屬良好，故備抵損失提列適足性尚屬允當，並無重大異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司備抵損失之提列係依據公司訂定之政策並參考客戶實際經營狀況與帳款收現情形予以評價，加上期後收回情形尚屬良好，其備抵損失提列情形應無重大異常之情事，另與採樣同業相較，該公司及其子公司應收款項週轉率及週轉天數均介於採樣同業之間，故尚無重大異常之情事。

(三)最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、母子公司備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

1.最近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

該公司及其子公司合併報表編製主體包含該公司本身暨其轉投資公司 Global Powertec Co., Ltd.(以下簡稱 Global Powertec)、PowerMemory Inc.(以下簡稱 Power Memory)及 Maxram Inc.(以下簡稱 Maxram)。其中該公司統籌集團經營策略，主要負責晶圓代工業務，包含記憶體及邏輯 IC 之研發、生產及銷售，而集團子公司依其定位各有不同，Global Powertec 屬投資控股公司，並無實質營運；PowerMemory 及 Maxram 則分別負責 Flash 及 DRAM 製程相關設計及研發，故合併存貨主要僅來自於該公司本身。

(1)存貨淨額及週轉率變動之合理性說明

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
營業收入淨額	35,897,121	45,684,615	45,865,144
營業成本	32,896,453	34,692,204	27,852,105
原料	2,317,005	3,111,065	3,559,325
在製品	4,460,246	4,533,721	4,898,778
製成品	854,139	938,400	318,139
期末存貨總額	7,631,390	8,583,186	8,776,242
備抵存貨跌價及呆滯損失	(1,245,893)	(764,575)	(458,006)
期末存貨淨額	6,385,497	7,818,611	8,318,236
存貨週轉率(次)	5.01	4.88	4.60
存貨週轉天數(天)	73	75	80

資料來源：108~109 年度及 110 年第三季係經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司主從事半導體晶圓代工服務，其原物料主要為矽晶圓、零配件、光阻、氣體、化學品及消耗材料等；製成品為記憶體產品與邏輯暨特殊應用產品；在製品為尚須製程加工及尚未完工產品之料件等，該公司及其子公司之產品主依銷售客戶訂單需求而備料生產，針對主要原料矽晶圓係以二至三個月安全庫存進行備料，製成品則考量製程之生產週期以一至三個月進行備貨，故其存貨變化與客戶訂單需求關係密切。

該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季之存貨淨額為 6,385,497 仟元、7,818,611 仟元及 8,318,236 仟元，其中 109 年底開始明顯呈現上升之趨勢，主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價至自谷底回溫，且為因應 110 年度訂單需求，故增加原料備貨所致，尚無重大異常情事。在合併存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司及其子公司於 108~109 年度及 110 年截至第三季之合併存貨週轉率分別為 5.01 次、4.88 次及 4.60 次；週轉天數分別為 73 天、75 天及 80 天，109 年度及 110 年截至第三季存貨週轉率下降，則主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價至自谷底回溫，自 109 年度開始為因應 110 年度訂單需求故積極增加原料備貨，使平均存貨淨額提升所致。

綜上所述，該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季之存貨總額、存貨週轉率及週轉天數主係因國際矽晶圓行情、產能規劃及庫存管理等因素影響，其變動情形尚屬合理。

(2)備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列政策合理性暨提列適足性之評估

A.存貨跌價損失與呆滯損失提列政策

該公司及其子公司採用國際會計準則公報第二號「存貨」規定，其存貨採用永續盤存制，平時按標準成本計價，結帳日再予以調整使其接近按加權平均法計算之成本，其存貨跌價評估方式，係採成本與淨變現價值孰低法衡量，比較成本與淨變現價值孰低時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

存貨呆滯損失提列比例如下：

(A)原料細分四類

(a)原料

90 天以下	91-180 天	181 天以上
0%	50%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

(b)物料(石英部分)

365 天以下	366-720 天	721 天以上
0%	50%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

(c)物料(石英除外)

180 天以下	181-365 天	366 天以上
0%	50%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

(d)設備維修備品

365 天以下	366-540 天	541-720 天	721-1080 天	1081-1440 天	1441 天以上
0%	20%	40%	60%	80%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

(B)在製品

因製程較短約 30~90 天，故無提列呆滯損失。

(C)製成品

180 天以下	181-365 天	366 天以上
0%	50%	100%

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司經參酌過往經營經驗，訂定存貨備抵跌價及呆滯損失提列政策，除按前揭成本與淨變現價值孰低法評價外，另針對各存貨組成項目庫齡超過一定天期之存貨，評估短期銷售或使用可能性不高時，提列 100%呆滯損失。

綜上評估,該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策係以國際會計準則為依據，並考量所處行業特性、產品性質、產品生命週期及過往產銷經驗等，經評估尚屬合理，並未發現重大異常之情事。

B.備抵存貨跌價與呆滯損失提列之適足性

單位：新臺幣仟元

項目	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	1,245,893	764,575	458,006
期末存貨總額(B)	7,631,390	8,583,186	8,776,242
提列比率(%) (A)/(B)	16.33	8.91	5.22

資料來源：108~109 年度及 110 年第三季係經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季之備抵存貨跌價及呆滯損失金額分別為 1,245,893 仟元、764,575 仟元及 458,006 仟元，占各期期末存貨總額比率分別為 16.33%、8.91%及 5.22%。109 年度及 110 年截至第三季提列比率逐漸下降至 5.22%，主係因 109 年度記憶體報價自谷底回溫，故迴

轉備抵存貨所致。該公司及其子公司為滿足客戶需求，提供客製化產品，原物料備料多為因應客戶訂單所需，且經參考存貨庫齡、存貨週轉率及存貨去化比率，該公司及其子公司備抵存貨跌價與呆滯損失提列之金額尚屬適足，且提列之情形無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司備抵存貨跌價及呆滯損失提列金額尚屬適足，應無重大異常情事。

C.存貨去化情形

該公司最近期經會計師核閱之財務報告所列第三季底，與刊印日前一個月所指九月底為同一時點，故不予分析。茲就上半年度截至九月底之存貨去化情形，分析如下：

單位：新臺幣仟元

項目	110 年 6 月底存貨金額	截至 110 年 9 月底存貨去化情形		截至 110 年 9 月底存貨未去化情形	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
原物料	3,486,248	2,030,645	58.25	1,455,603	41.75
在製品	4,758,945	4,758,111	99.98	834	0.02
製成品	386,592	347,441	89.87	39,151	10.13
合計	8,631,785	7,136,197	82.67	1,495,588	17.33

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司 110 年 6 月底存貨總額為 8,631,785 仟元，截至 110 年 9 月底存貨去化金額為 7,136,197 仟元，去化比率為 82.67%，未去化金額 1,495,588 仟元，未去化比率為 17.33%，茲就各項存貨之去化情形分別說明如下：

(A)原物料

原物料存貨總額為 3,486,248 仟元，占期末存貨總額 40.39%，截至 110 年 9 月底存貨去化金額為 2,030,645 仟元，去化比率為 58.25%。未去化之原物料金額為 1,455,603 仟元，原物料主要為矽晶圓、零配件、光阻、氣體及消耗材料等，主係依據客戶訂單及策略性備料，提前採購所需原物料所致，經評估尚無重大異常情事。

(B)在製品

在製品存貨總額為 4,758,945 仟元，占期末存貨總額 55.13%，截至 110 年 9 月底存貨去化金額為 4,758,111 仟元，去化比率為 99.98%。未去化之在製品金額為 834 仟元，未去化比率微小，故不予進一步分析。

(C)製成品

製成品總額為 386,592 仟元，占期末存貨總額 4.48%，截至 110 年 9 月

底存貨去化金額為 347,441 仟元，去化比率為 89.87%。製成品係依照客戶訂單需求及考量公司生產週期安排生產，並受客戶取貨時點及品質檢驗是否合格影響製成品去化進度。未去化之製成品金額為 39,151 仟元，主係因部分產品完工後尚未能符合公司品質標準或客戶允收標準，該公司及其子公司已積極處理，經評估尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司存貨去化情形尚屬合理，並無異常之情事。

(3)與同業比較

單位：新臺幣仟元；次；天；%

項目 \ 年度		108 年度	109 年度	110 年截至第三季
營業成本	力積電	32,896,453	34,692,204	27,852,105
	聯電	126,886,669	137,823,813	註 3
	世界	17,953,285	21,874,918	註 3
	華邦電	35,857,582	43,643,035	註 3
期末存貨總額(B)	力積電	7,631,390	8,583,186	8,776,242
	聯電	註 1	註 1	註 1
	世界	註 1	註 1	註 1
	華邦電	註 1	註 1	註 1
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	力積電	1,245,893	764,575	458,006
	聯電	註 1	註 1	註 1
	世界	註 1	註 1	註 1
	華邦電	註 1	註 1	註 1
期末存貨淨額	力積電	6,385,497	7,818,611	8,318,236
	聯電	21,714,802	22,552,486	註 3
	世界	3,107,612	3,072,362	註 3
	華邦電	10,332,143	14,141,414	註 3
備抵存貨跌價及呆滯損失提列比率(%)(A)/(B)	力積電	16.33	8.91	5.22
	聯電	註 1	註 1	註 1
	世界	註 1	註 1	註 1
	華邦電	註 1	註 1	註 1
存貨週轉率(次)(註 2)	力積電	5.01	4.88	4.60
	聯電	6.36	6.23	註 3
	世界	5.50	7.08	註 3
	華邦電	3.38	3.57	註 3
存貨週轉天數(天)	力積電	73	75	80
	聯電	58	59	註 3
	世界	67	52	註 3
	華邦電	109	103	註 3

資料來源：108~109 年度及 110 年第三季係經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

註 1：合併財務報告中並未揭示存貨總額暨備抵存貨跌價及呆滯損失金額。
註 2：存貨週轉率係以營業成本除以平均存貨淨額計算。
註 3：截至刊印日止，同業尚未公告第三季財務報告。

該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季之存貨週轉率分別為 5.01 次、4.88 次及 4.60 次，週轉天數分別為 73 天、75 天及 80 天，該公司及其子公司係以接單式生產及計畫性生產兼具之生產方式安排生產排程及採購作業，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，存貨週轉率主要受到因訂單排程及客製化產品須提前備料，因而略有增減。與採樣同業相較，108~109 年度及 110 年截至第三季皆介於採樣同業公司間，整體而言尚無重大異常之情事。

該公司及其子公司 108~109 年度及 110 年截至第三季之備抵存貨跌價及呆滯損失占存貨總額比率分別為 16.33%、8.91%及 5.22%，與採樣同業相較，因同業財務報告皆採淨額表達而無法取具數據，故無法比較分析。由於該公司及其子公司係以訂單式生產及計畫性生產為主，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，產品客製化程度高，具多樣化特性，故其在製品及製成品大多均有明確的客戶訂單歸屬，且該公司之備抵存貨跌價及呆滯損失係以國際財務會計準則為依歸，並參酌過去之經營經驗、各地市場銷售情形及以往年度實際發生存貨呆滯之庫齡，擬訂備抵提列政策後據以提列，經會計師評價備抵存貨跌價損失及呆滯損失提列金額尚屬適足。

綜上所述，該公司及其子公司備抵損失之提列係依據公司訂定之政策並參考客戶行業特性與存貨情形予以評價，其備抵損失提列情形應無重大異常之情事，另與採樣同業相較，該公司及其子公司存貨週轉率及週轉天數均介於採樣同業之間，故尚無重大異常之情事。

2.最近期及最近二個會計年度，發行公司之個體財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

相關評估請參閱前述「1.近期及最近二個會計年度，發行公司之財務報告存貨淨額變動之合理性、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估」說明。

(四)發行人最近期及最近三個會計年度財務報告之業績概況

1.列表並說明最近期及最近三個會計年度財務報告營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新臺幣仟元

項目＼年度		107 年度	108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
		金額	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)
營業收入	力積電	49,913,779	35,897,121	(28.08)	45,684,615	27.27	45,865,144	35.65
	聯電	151,252,571	148,201,641	(2.02)	176,820,914	19.31	註	—
	世界	28,928,094	28,286,072	(2.22)	33,131,202	17.13	註	—

項目	年度	107 年度	108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
		金額	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)	金額	成長率(%)
	華邦電	51,190,323	48,771,434	(4.73)	60,683,171	24.42	註	—
營業毛利	力積電	15,280,265	3,000,668	(80.36)	10,992,411	266.33	18,013,039	126.97
	聯電	22,840,027	21,314,972	(6.68)	38,997,101	11.93	註	—
	世界	10,168,270	10,332,787	1.62	11,256,284	3.26	註	—
	華邦電	19,151,103	12,913,852	(32.57)	17,040,136	31.95	註	—
營業利益	力積電	8,886,597	(2,098,779)	(123.62)	5,744,244	373.69	12,551,292	210.26
	聯電	5,797,232	4,689,850	(19.10)	22,007,407	11.69	註	—
	世界	7,154,708	6,909,389	(3.43)	7,416,206	1.79	註	—
	華邦電	7,926,697	1,255,209	(84.16)	1,627,291	29.64	註	—

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

註：截至刊印日止，同業尚未公告第三季財務報告。

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工，包含顯示高壓邏輯製程((High Voltage；主要應用於手機、平板、TV 及電子紙等驅動 IC 及觸控驅動 IC 等產品)、電源管理晶片產品(Power IC)、分離式元件產品(Discrete)、CMOS 影像感測器產品(CIS；CMOS Image Sensor)、嵌入式非揮發性記憶體之晶圓代工服務；以及記憶體產品晶圓代工，包含動態隨機存取記憶體產品(DRAM)、快閃記憶體產品(NAND Flash、NOR Flash)之晶圓代工服務。

檢視目前上市櫃公司，選樣條件以同屬從事半導體晶圓代工服務或記憶體製造之公司，並參酌營業項目較為相近者，選取聯電(上市公司，股票代號：2303)、世界(上櫃公司，股票代號：5347)及華邦電(上市公司，股票代號：2344)作為採樣公司。其中，聯電主要係提供半導體晶圓代工之服務，專注於邏輯及特殊技術，包含電子行業的各項主要應用產品生產晶片；世界主要係提供半導體晶圓代工之服務，包含邏輯、混合訊號、高壓、超高壓、BCD、SOI、嵌入式非揮發性記憶體等製程，主要代工產品為 LCD 驅動 IC、電源管理 IC 及指紋辨識 IC 等；華邦電主要從事利基型記憶體 IC 設計、製造與銷售，產品包括利基型記憶體(Specialty DRAM)、行動記憶體(Mobile DRAM)以及編碼型快閃記憶體(Code Storage Flash Memory)等。茲就該公司及其子公司與採樣同業聯電、世界及華邦電之營業收入、營業毛利及營業利益比較說明如下：

(1)營業收入

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季之營業收入分別為 49,913,779 仟元、35,897,121 仟元、45,684,615 仟元及 45,865,144 仟元，營業收入成長率分別為(28.08)%、27.27%及 35.65%，108 年度營業收入降低 28.08%，主係中美貿易影響半導體產業之不確定性因素繼續蔓延，邏輯產品終端客戶拉貨需求降低，加上記憶體市況不佳、單位售價(ASP)下跌等因素影響，致當年度營業收入相較 107 年度下降 28.08%。109 年度營收較 108 年度增加 9,787,494 仟

元，成長幅度為 27.27%，主係邏輯 IC 出貨暢旺，且記憶體報價自谷底回溫，且該公司及其子公司透過優化客戶結構，營業收入亦隨之增加。110 年截至第三季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，此外，該公司及其子公司並透過優化客戶及產線組合，營業收入相較去年同期增加 35.65%。

與採樣同業相較，108 年度該公司及其子公司與採樣同業皆因中美貿易戰延續導致半導體產業呈現衰退趨勢，惟該公司及其子公司衰退幅度較採樣同業高，主係 108 年度該公司及其子公司因整體產能利用率偏低、記憶體市況不佳、單位售價(ASP)下跌所致。109 年度該公司及其子公司與採樣同業皆較去年同期呈現成長優勢，緣於中美貿易爭端趨緩和、以及 5G、車用電子及物聯網等新應用領域發展，致全球半導體市場自 108 年度之低迷逐漸復甦，其中力積電成長幅度大於採樣同業，主係記憶體產業自從谷底回升、受惠記憶體及邏輯報價同步上揚、及 108 年度相對同業基期較低所致。110 年截至第三季全球半導體產業延續 109 年的成長態勢，受惠於 5G、車用電子及物聯網、人工智慧等晶片需求，及新冠肺炎疫情帶動居家工作、遠距教學、伺服器等宅經濟相關資訊產品，該公司及其子公司之營業收入均呈現成長態勢。整體而言，該公司及其子公司與採樣同業營業收入變動均呈相同趨勢，尚無異常之情事。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及 110 年截至第三季營業收入消長，主係隨著半導體產業市況、優化客戶及產線組合等因素而變化，其變動情形尚屬合理；與採樣同業趨勢相同，惟增減幅度互為優劣，尚無重大異常情事。

(2)營業毛利

年度 公司	107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
	金額	毛利率(%)	金額	毛利率(%)	金額	毛利率(%)	金額	毛利率(%)
力積電	15,280,265	30.61	3,000,668	8.36	10,992,411	24.06	18,013,039	39.27
聯電	22,840,027	15.10	21,314,972	14.38	38,997,101	22.05	註	—
世界	10,168,270	35.15	10,332,787	36.53	11,256,284	33.97	註	—
華邦電	19,151,103	37.41	12,913,852	26.48	17,040,136	28.08	註	—

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。
註：截至刊印日止，同業尚未公告第三季財務報告。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季之營業毛利分別為 15,280,265 仟元、3,000,668 仟元、10,992,411 仟元及 18,013,039 仟元，分別較去年同期變化為(80.36)%、266.33%及 126.97%，營業毛利主要隨營收規模增減而變動，毛利率分別為 30.61%、8.36%、24.06%及 39.27%。108 年度營業毛利較

107 年度減少 12,279,597 仟元，減少幅度 80.36%，主係半導體產業呈現衰退趨勢致整體訂單減少、單位售價(ASP)下跌，整體產能使用率下降，使得產品之單位成本上升，導致營業毛利及毛利率下降。109 年度營業毛利較 108 年度增加 7,991,743 仟元，成長幅度達 266.33%，主要受惠於終端市場的需求使訂單增加，產能利用率提升、單位售價(ASP)回升及持續推進製程技術所致。110 年截至第三季營業毛利較去年同期增加 10,076,902 仟元，成長幅度 126.97%，主係受惠產能利用率近滿載、持續推進製程技術以降低成本，及晶圓代工及記憶體漲價效應，持續推升毛利率所致。

與採樣同業相較，聯電旗下共有 7 座 8 吋廠以及 4 座 12 吋廠，主要從事成熟及特殊製程的晶圓製造，其中 109 年度毛利率大幅成長，主係受惠於終端市場需求增加，自 109 年第三季起接單暢旺且產能利用率近滿載，加上成功整合日本 USJC 12 吋業務，毛利率成長至 22.05%。世界主要擁有四座 8 吋廠以成熟製程為主，110 年度購入友達 L3B 廠成為旗下第 5 座晶圓廠，主要為生產 IGBT 等電源管理產品， 因 8 吋晶圓廠主要設備已折舊完畢，使得固定成本較低，故最近三年度之毛利率介於 33.97%~36.53%，相較其他採樣同業為高。華邦電主要從事利基型記憶體 IC 設計、製造與銷售，108 年度因記憶體產業受總體經濟影響，庫存去化緩慢、市場需求不如預期，毛利率下降至 26.48%。109 年度毛利率微幅上升至 28.08%，主係受惠於 109 年度第四季記憶體毛利率上揚所致。110 年截至第三季因半導體需求增溫，各晶圓代工廠產能處於滿載水準，及由於三大記憶體廠商(三星、SK 海力士、美光)在 109 年下半年將舊製程利基型 DRAM 產能移轉至 CMOS 影像感測器製程後，使得 DRAM 市場供給產生短缺，在單位售價(ASP)及產能利用率提升之下，該公司及其子公司與採樣同業毛利率均呈同幅成長。

該公司及其子公司與採樣同業因銷售產品、銷售策略及生產模式不同，造成營業毛利率有所差異，其中除 108 年度因整體產能利用率偏低，致毛利率均低於採樣同業外，107、109 年度之營業毛利率均介於採樣同業之間。依上述分析營業毛利率之變動尚無發現重大異常情事。

(3)營業(損)益

年度 公司	107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
	金額	營業利益率(%)	金額	營業利益率(%)	金額	營業利益率(%)	金額	營業利益率(%)
力積電	8,886,597	17.80	(2,098,779)	(5.85)	5,744,244	12.57	12,551,292	27.37
聯電	5,797,232	3.83	4,689,850	3.16	22,007,407	12.45	註	—
世界	7,154,708	24.73	6,909,389	24.43	7,416,206	22.38	註	—
華邦電	7,926,697	15.48	1,255,209	2.57	1,627,291	2.68	註	—

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告之財務報告。

註：截至刊印日止，同業尚未公告第三季財務報告

項目	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季

推銷費用	461,925	300,790	335,218	370,006
管理費用	2,736,267	2,008,972	1,890,511	2,363,702
研究發展費用	3,453,483	2,962,370	3,234,765	2,951,790
營業費用	6,651,675	5,272,132	5,460,494	5,685,498
營業費用率(%)	13.33	14.69	11.95	12.40

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季之營業費用分別為 6,651,675 仟元、5,272,132 仟元、5,460,494 仟元及 5,685,498 仟元，營業費用率分別為 13.33%、14.69%、11.95%及 12.40%；107~109 年度及 110 年截至第三季之營業(損)益分別為 8,886,597 仟元、(2,098,779)仟元、5,744,244 仟元及 12,551,292 仟元，營業(損)益率分別為 17.80%、(5.85)%、12.57%及 27.37%。

推銷費用主要係為業務人員之薪資及相關費用、園區管理費、間接材料及折舊費用等，108 年度推銷費用相較 107 年度減少 161,135 仟元，主要係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金及員工酬勞等帳列薪資費用減少 128,315 仟元，及園區管理費減少 29,359 仟元。109 年推銷費用增加 34,428 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 17,530 仟元且因營收成長致園區管理費增加 18,236 仟元所致。110 年截至第三季推銷費用相較去年同期增加 123,223 仟元，主係因業績成長、調薪及人員增加，致獎金及員工認股權帳列之薪資費用增加 43,456 仟元，員工酬勞增加 39,761 仟元；園區管理費增加 23,121 仟元。

管理費用主要係間接人員之薪資費用、折舊費用、環保費用、電腦使用費及專業服務費(勞務費)等，108 年度管理費用減少 727,295 仟元，主係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 107 年度減少 277,427 仟元，及員工酬勞減少 410,830 仟元。109 年度管理費用減少 118,461 仟元，主係竹南廠於 108 年 5 月前屬建廠期間，期間費用 318,118 仟元帳列管理費用，108 年 6 月起帳列製造費用，故 109 年管理費用減少。排除竹南廠建廠費用後，管理費用增加 199,657 仟元，主係獎金及員工酬勞增加。110 年截至第三季管理費用相較去年同期增加 988,334 仟元，主係業績成長、調薪及銅鑼廠建廠人員增加，致獎金及員工認股權帳列之薪資費用增加 364,245 仟元，員工及董監酬勞增加 563,091 仟元，租金費用較前期增加 21,505 仟元，主係因公司銅鑼廠建廠所需短期租用銅鑼園區土地以作為土方暫存放置之用，致費用增加。

研究發展費用主要為研發人員之薪資費用、專業服務費、電腦使用費、製程及技術改善費用、折舊費用、光罩費用及間接材料等，108 年度研究發展費用減少 491,113 仟元，主係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 107 年度減少 516,765 仟元。109 年研究發展費用增加 272,395 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 288,095 仟元所致。110 年截至第三季研究發展費用相較去年同期增加 573,547

仟元，主係因業績成長、調薪及人員增加，致獎金及員工認股權帳列之薪資費用增加 202,671 仟元，員工酬勞增加 320,647 仟元。因新增研發設備，折舊費用增加 60,226 仟元，因配合研發專案發生時程，專業服務費減少 80,264 仟元，製程及技術改善增加 28,502 仟元，光罩減少 21,241 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司營業費用變化，主係隨著該年度營收及稅前損益減少及增加，致間接人員之績效獎金、員工酬勞等薪資費用同幅增減變動所致。

與採樣同業相較，該公司及其子公司 108 年度之營業利益率低於所有採樣同業，107、109 年度則介於採樣同業之間。該公司及其子公司於 108 年度因整體產能利用率偏低，毛利率由 30.61%降至 8.36%，致營業利益率為負且低於採樣同業，而 109 年度主係邏輯 IC 出貨暢旺，且記憶體報價自谷底回溫及該公司及子公司持續產品組合優化致營收成長，且成本費用控管得宜，致 109 年度營業費用率下降至 11.95%，營業利益率成長至 12.57%，其營業利益率已與採樣同業聯電相近。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度之營業利益率與採樣同業相較互有高低，主要係因各公司之營運模式、銷售產品及費用控管不盡相同，導致營業利益率亦有所差異，惟該公司及其子公司透過優化客戶及產線組合、推進製程技術、調升代工價格與產能利用率，使得營業利益率逐年成長，持續提升獲利能力，經評估應無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司最近三年度及 110 年截至第三季營業收入、營業毛利及營業利益之變化情形，尚無重大異常之情事。

2.列表並說明最近期及最近三個會計年度財務報告以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

主要產品別銷貨收入變動表

單位：新臺幣仟元

年度 產品別	107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
邏輯暨特殊應用產品	21,590,848	43.26	16,703,015	46.53	25,657,228	56.16	25,395,715	55.37
記憶體產品（片）	16,337,034	32.73	10,809,807	30.11	14,049,468	30.75	13,691,907	29.85
記憶體產品（顆）	11,985,897	24.01	8,384,299	23.36	5,977,919	13.09	6,777,522	14.78
合計	49,913,779	100.00	35,897,121	100.00	45,684,615	100.00	45,865,144	100.00

主要產品別銷貨成本變動表

單位：新臺幣仟元

年度 產品別	107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
邏輯暨特殊應用產品	15,791,962	45.60	13,388,912	40.70	17,978,616	51.82	15,326,330	55.03
記憶體產品（片）	10,671,327	30.81	8,655,511	26.31	10,873,832	31.35	9,176,814	32.95
記憶體產品（顆）	8,170,225	23.59	10,852,030	32.99	5,839,756	16.83	3,348,961	12.02
合計	34,633,514	100.00	32,896,453	100.00	34,692,204	100	27,852,105	100.00

主要產品別銷貨毛利變動表

單位：新臺幣仟元

年度 產品別	107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
邏輯暨特殊應用產品	5,798,886	37.95	3,314,103	110.45	7,678,612	69.85	10,069,385	55.90
記憶體產品（片）	5,665,707	37.08	2,154,296	71.79	3,175,636	28.89	4,515,093	25.07
記憶體產品（顆）	3,815,672	24.97	(2,467,731)	(82.24)	138,163	1.26	3,428,561	19.03
合計	15,280,265	100.00	3,000,668	100.00	10,992,411	100.00	18,013,039	100.00

資料來源：該公司及其子公司提供。

該公司及其子公司之主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工及記憶體產品晶圓代工，另由於記憶體單位區分為片及顆，故主要產品別分別為邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品(片)及記憶體產品(顆)。茲就該公司及其子公司主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形說明如下：

(1)邏輯暨特殊應用產品

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季邏輯暨特殊應用產品之營業收入分別為 21,590,848 仟元、16,703,015 仟元、25,657,228 仟元及 25,395,715 仟元，占整體營業收入淨額之比率分別為 43.26%、46.53%、56.16%及 55.37%。108 年度邏輯暨特殊應用產品營業收入相較 107 年度減少 4,887,833 仟元，降低幅度為 22.64%，主係因國際間貿易緊張氛圍帶來不確定性，且消費型裝置如液晶電視、筆記型電腦、平板電腦、智慧手機和其他主要應用的顯示模組需求已達到飽和，終端客戶拉貨意願降低，致整體需求減少，且 108 年度平均單價相較 107 年度亦呈現下滑。109 年度邏輯暨特殊應用產品營業收入相較 108 年度增加 8,954,213 仟元，成長幅度達 53.61%，受惠於 5G 產業、車用市場及人工智慧等應用需求增加，為半導體產業注入成長動能，致該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺，營收隨之大幅成長。110 年截至第三季邏輯暨特殊應用產品營業收入相較去年同期增加 6,707,494 仟元，主係受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之

驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季邏輯暨特殊應用產品之營業成本分別為 15,791,962 仟元、13,388,912 仟元、17,978,616 仟元及 15,326,330 仟元，營業毛利分別為 5,798,886 仟元、3,314,103 仟元、7,678,612 仟元及 10,069,385 仟元，毛利率分別為 26.86%、19.84%、29.93%及 39.65%。108 年度營業毛利較 107 年度減少 2,484,783 仟元，變動比率為(42.85)%，毛利率由 26.86%下降至 19.84%，主係因邏輯暨特殊應用產品應用終端需求趨緩，訂單減少導致營業毛利及毛利率下降。109 年度營業毛利較 108 年度增加 4,364,509 仟元，變動比率為 131.70%，毛利率由 19.84%上升至 29.93%，主係受惠於半導體終端需求增長之效益，使訂單量增加、整體產能利用率提升，致營業成本下降，毛利率隨之上升。110 年截至第三季營業毛利較去年同期增加 4,650,766 仟元，變動比率為 85.83%，毛利率大幅上升至 39.65%，主係全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能利用率達滿載、且報價隨之上揚所致。

(2)記憶體產品(片)

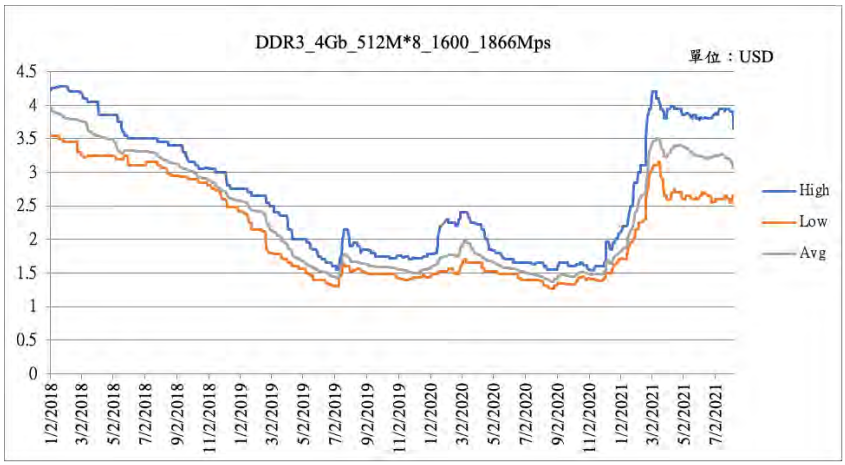
該公司及其子公司銷售之記憶體產品(片)主要係替具有設計能力卻沒有製造工廠客戶代工，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季記憶體產品(片)之營業收入分別為 16,337,034 仟元、10,809,807 仟元、14,049,468 仟元及 13,691,907 仟元，占整體營業收入之比率分別為 32.73%、30.11%、30.75%及 29.85%。108 年度記憶體產品(片)營業收入相較 107 年度減少 5,527,227 仟元，降低幅度為 33.83%，主係 107 年底客戶端與記憶體供應商的庫存水位皆達到相對高點，且 108 年度受到美中貿易戰造成供應鏈趨於保守，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱，致記憶體價格及銷售量在 108 年上半年度快速滑落。109 年度記憶體產品(片)營業收入相較去年同期增加 3,239,661 仟元，變動幅度為 29.97%，主係由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，其中 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，且由於三大記憶體廠商(三星、SK 海力士、美光)在 109 年下半年將舊製程 DRAM 產能移轉至 CMOS 影像感測器製程後，使得 DRAM 市場供給產生短缺，帶動需求增加所致。110 年截至第三季記憶體產品(片)營業收入相較去年同期增加 2,950,382 仟元，變動幅度為 27.47%，主要受惠需求增加單位報價持續上揚。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季記憶體產品(片)之營業成本分別為 10,671,327 仟元、8,655,511 仟元、10,873,832 仟元及 9,176,814 仟元，營業毛利分別為 5,665,707 仟元、2,154,296 仟元、3,175,636 仟元及 4,515,093 仟元，毛利率分別為 34.68%、19.93%、22.60%及 32.98%，108 年度營業毛利較 107 年度減少 3,511,411 仟元，變動比率為(61.98)%，毛利率下降至 19.93%，主係因記憶體市場需求疲軟，處於供過於求的狀態，故該公司及其子公司訂單量減少、整體產能使用率大幅降低所致。109 年度營業毛利較 108 年度增加 1,021,340 仟元，變動比率為 47.41%，主係由於 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，使訂單量增加、整體產能利用率提升，致營業成本下降，

毛利率成長至 22.60%。110 年截至第三季除承接 109 年度產業整體態勢外，且單位報價持續上揚，毛利率更進而成長至 32.98%。

(3)記憶體產品(顆)

該公司及其子公司銷售之記憶體產品(顆)主要是銷售該公司所設計產品，非客製化產品，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季記憶體產品(顆)之營業收入分別為 11,985,897 仟元、8,384,299 仟元、5,977,919 仟元及 6,777,522 仟元，占整體營業收入之比率分別為 24.01%、23.36%、13.09%及 14.78%，主係為 PC DRAM 及包裝元件等。108 年度記憶體產品(顆)之營業收入較 107 年度減少 3,601,598 仟元，變動比率(30.05)%，主係 108 年度因智慧型手機成長趨緩、終端需求降溫等因素，出現供過於求的狀況，致平均銷售價格(ASP)下跌。109 年度由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，致記憶體市況雖至谷底回溫，惟 PC 應用相關成長力道相對持平，且該公司及其子公司為逐漸降低記憶體價格波動過大產生之營運風險，108 年度開始改變銷售產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，故記憶體銷售數量相較前一年度略為降低，致 109 年度記憶體產品(顆)營業收入占整體營業收入比率降至 13.09%。110 年截至第三季記憶體產品(顆)之營業收入相較去年同期增加 2,395,995 仟元，變動比率為 54.68%，主係標準型 DRAM 受惠於新冠肺炎疫情持續推動筆電出貨動能單位報價持續上揚所致。另查詢 TrendForce 最近三年度及最近期記憶體報價資料，市場趨勢與該公司及其子公司記憶體產品(顆)之營業收入變化尚無重大異常之情事。



該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季記憶體產品(顆)之營業成本分別為 8,170,225 仟元、10,852,030 仟元、5,839,756 仟元及 3,348,961 仟元，營業毛利分別為 3,815,672 仟元、(2,467,731)仟元、138,163 仟元及 3,428,561 仟元，毛利率分別為 31.83%、(29.43)%、2.31%及 50.59%，108 年度營業毛利較 107 年度大幅減少 6,283,403 仟元，毛利率下降至(29.43)%，主係因記憶體市場需求疲軟，處於供過於求的狀態，故該公司及其子公司訂單量減少、整體產能使用率大幅降低所致，此外，記憶體產品(顆)主要應用之 PC DRAM 終端報價跌幅甚鉅，故毛利率呈現負數。109 年度由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消

長下，致記憶體市況至谷底回溫，記憶體銷售單價(ASP)微幅上漲，但該公司為逐漸降低 DRAM 價格波動過大產生之營運風險，故改變銷售產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，記憶體(顆)之銷售數量因而減少以致銷售金額相較去年度下滑，但惟調整產能配置後使記憶體產線之產能利用率提升，致營業成本下降，毛利率由負轉為正。110 年截至第三季受惠終端需求增溫、產能利用率滿載，且單位報價持續上揚，毛利率大幅成長至 50.59%。

綜上所述，107~109 年度及 110 年截至第三季主要產品別之營業收入、營業成本及營業毛利變化趨勢，尚無重大異常之情事。

3.最近期及最近三個會計年度財務報告營業收入或毛利率變動達百分之二十以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

該公司及其子公司最近期及最近三個會計年度之營業收入及毛利率變動率如下表所示：

單位：新臺幣仟元

項目＼年度	107 年度	108 年度		109 年度		109 年截至第三季	110 年截至第三季	
	金額	金額	變動率	金額	變動率	金額	金額	變動率
營業收入	49,913,779	35,897,121	(28.08)	45,684,615	27.27	33,811,273	45,865,144	35.65
營業毛利	15,280,265	3,000,668	(80.36)	10,992,411	266.33	7,936,137	18,013,039	126.97
毛利率(%)	30.61	8.36	(72.69)	24.06	187.80	23.47	39.27	67.32

資料來源：該公司及其子公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告

依上表所示，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季之營業收入及毛利率變動率均達 20%以上，故應進行價量分析。茲將主要產品邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品(片)及記憶體產品(顆)之價量變動情形及合理性分析說明如下：

單位：新臺幣仟元

主要產品	分析項目	107 及 108 年度	108 及 109 年度	109 年截至第三季及 110 年截至第三季
邏輯暨特殊應用產品	(一)營業收入差異分析：			
	P(Q’−Q)	(4,140,766)	9,687,758	2,991,645
	Q(P’−P)	(924,340)	(464,269)	3,203,092
	(P’−P)(Q’−Q)	177,273	(269,276)	512,757
	P’Q’−PQ	(4,887,833)	8,954,213	6,707,494
	(二)營業成本差異分析：			
	P(Q’−Q)	(3,028,636)	7,765,576	2,124,222
	Q(P’−P)	774,032	(2,010,045)	(58,181)
	(P’−P)(Q’−Q)	(148,446)	(1,165,827)	(9,314)
	P’Q’−PQ	(2,403,050)	4,589,704	2,056,728
	(三)毛利變動金額：	(2,484,783)	4,364,509	4,650,766

主要產品	分析項目	107 及 108 年度	108 及 109 年度	109 年截至第三季及 110 年截至第三季
記憶體產品(片)	(一)營業收入差異分析：			
	P(Q'−Q)	(4,002,004)	4,149,881	417,041
	Q(P'−P)	(2,020,070)	(657,721)	2,438,660
	(P'−P)(Q'−Q)	494,847	(252,499)	94,681
	P'Q'−PQ	(5,527,227)	3,239,661	2,950,382
	(二)營業成本差異分析：			
	P(Q'−Q)	(2,614,103)	3,322,848	322,168
	Q(P'−P)	792,397	(798,127)	535,905
	(P'−P)(Q'−Q)	(194,110)	(306,400)	20,807
	P'Q'−PQ	(2,015,816)	2,218,321	878,880
	(三)毛利變動金額：	(3,511,411)	1,021,340	2,071,502
記憶體產品(顆)	(一)營業收入差異分析：			
	P(Q'−Q)	3,542,855	(2,461,751)	(897,722)
	Q(P'−P)	(5,514,460)	78,386	4,142,457
	(P'−P)(Q'−Q)	(1,629,993)	(23,015)	(848,740)
	P'Q'−PQ	(3,601,598)	(2,406,380)	2,395,995
	(二)營業成本差異分析：			
	P(Q'−Q)	2,414,999	(3,186,312)	(882,576)
	Q(P'−P)	205,935	(2,584,936)	(95,664)
	(P'−P)(Q'−Q)	60,871	758,974	19,600
	P'Q'−PQ	2,681,805	(5,012,274)	(958,639)
	(三)毛利變動金額：	(6,283,403)	2,605,894	3,354,634
毛利變動金額合計數		(12,279,597)	7,991,743	10,076,902

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：單位係為換算 12 吋約當片。

註 2：P'、Q'為本期之單價及數量；P、Q 為前期之單價及數量

(1)邏輯暨特殊應用產品

A.107 及 108 年度

(A)營業收入減少 4,887,833 仟元

108 年度主係因國際間貿易緊張氛圍帶來不確定性，且消費型裝置如液晶電視、筆記型電腦、平板電腦、智慧手機和其他主要應用的顯示模組需求已達到飽和，終端客戶拉貨意願降低致整體需求減少，且 108 年度平均單價相較 107 年度亦呈現下滑，故產生數量不利差異 4,140,766 仟元及價格不利差異 924,340 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 177,273 仟元。

(B)營業成本減少 2,403,050 仟元

108 年度主係因邏輯暨特殊應用產品應用終端需求趨緩，因銷售量下降，產生數量有利差異 3,028,636 仟元；108 年度因當年度整體產能利用率

下降，使單位成本上升，產生價格不利差異 774,032 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 148,446 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 108 年度邏輯暨特殊應用產品之營業毛利較 107 年度減少 2,484,783 仟元。

B.108 及 109 年度

(A)營業收入增加 8,954,213 仟元

109 年度受惠於 5G 產業、車用市場及人工智慧等應用需求增加，為半導體產業注入成長動能，致該公司及其子公司邏輯 IC 出貨暢旺，故產生數量有利差異 9,687,758 仟元；109 年度邏輯暨特殊應用產品市況雖相較於 108 年度已逐漸回溫，惟消費性電子及面板等終端應用方面，於上半年度仍受到經濟不確定性風險因素之影響，且受美金匯率報價影響，致全年度平均售價仍微幅低於 108 年度，產生價格不利差異 464,269 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 269,276 仟元。

(B)營業成本增加 4,589,704 仟元

109 年度主係受惠於半導體終端需求增長之效益，使邏輯暨特殊應用產品訂單量增加，產生數量不利差異 7,765,576 仟元；此外，隨訂單量增加致整體產能利用率提高，使單位成本下降，產生價格有利差異 2,010,045 仟元，銷售量增加且單位成本下降之情況下，銷貨成本產生有利組合差異 1,165,827 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 109 年度邏輯暨特殊應用產品之營業毛利較 108 年度增加 4,364,509 仟元。

C.110 年截至第三季及 109 年截至第三季

(A)營業收入增加 6,707,494 仟元

110 年截至第三季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能利用率達滿載、且報價隨之上揚，公司調整生產產品組合產生數量有利差異 2,991,645 仟元；報價隨上揚產生價格有利差異 3,203,092 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 512,757 仟元。

(B)營業成本增加 2,056,728 仟元

110 年截至第三季受惠於半導體產業持續熱絡，全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能利用率達滿載，銷售數量增加產

生成本數量不利差異 2,124,222 仟元；單位成本減少產生價格有利差異 58,181 仟元，銷貨成本產生有利組合差異 9,314 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 110 年截至第三季邏輯暨特殊應用產品之營業毛利較 109 年截至第三季增加 4,650,766 仟元。

(2)記憶體產品(片)

A.107 及 108 年度

(A)營業收入減少 5,527,227 仟元

108 年度記憶體產品(片)營業收入減少，主係 107 年底客戶端與記憶體供應商的庫存水位皆達到相對高點，且受到美中貿易戰造成供應鏈趨於保守，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱，是以在 108 年度終端庫存水位較高、採購動能轉弱、整體供過於求情況下，導致記憶體價格及銷售量在 108 年上半年度快速滑落，故產生數量不利差異 4,002,004 仟元及價格不利差異 2,020,070 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 494,847 仟元。

(B)營業成本減少 2,015,816 仟元

108 年度因記憶體市場需求疲軟，致銷售數量減少，產生數量有利差異 2,614,103 仟元，及因當年度整體產能利用率下降，使單位成本上升，產生價格不利差異 792,397 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 194,110 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 108 年度記憶體產品(片)之營業毛利較 107 年度減少 3,511,411 仟元。

B.108 及 109 年度

(A)營業收入增加 3,239,661 仟元

109 年度主係由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，其中 5G 等終端應用市場需求暢旺，帶動利基型記憶體市場呈現復甦，故記憶體產品(片)銷售數量相較 108 年度增加，產生數量有利差異 4,149,881 仟元，而記憶體報價雖於 109 年度第四季至谷底回升，惟受到美金報價匯率下跌之不利影響，故產生價格不利差異 657,721 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 252,499 仟元。

(B)營業成本增加 2,218,321 仟元

109 年度因記憶體銷售數量相較前一年度增加，產生數量不利差異 3,322,848 仟元，此外，該公司及其子公司 109 年度整體產能利用率提高，使單位成本下降，價格有利差異 798,127 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 306,400 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 109 年度記憶體產品(片)之營業毛利較 108 年度增加 1,021,340 仟元。

C.110 年截至第三季及 109 年截至第三季

(A)營業收入增加 2,950,382 仟元

110 年截至第三季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能持續滿載，記憶體產品(片)銷售數量相較 109 年前三季增加，產生數量有利差異 417,041 仟元，而記憶體報價持續上揚故產生價格有利差異 2,438,660 仟元，價量相乘效果產生組合有利差異 94,681 仟元。

(B)營業成本增加 878,880 仟元

110 年截至第三季因記憶體銷售數量相較去年同期增加，產生數量不利差異 322,168 仟元，單位成本上升產生價格不利差異 535,905 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 20,807 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 110 年截至第三季記憶體產品(片)之營業毛利較 109 年截至第三季增加 2,071,502 仟元。

(3)記憶體產品(顆)

A.107 及 108 年度

(A)營業收入減少 3,601,598 仟元

108 年度記憶體產品(顆)營業銷售價格下降，主係 107 年底客戶端與記憶體供應商的庫存水位皆達到相對高點，且受到美中貿易戰造成供應鏈趨於保守，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求皆轉弱，導致記憶體價格快速滑落，產生價格不利差異 5,514,460 仟元；在 108 年度 DRAM 價格相對較低，許多 DRAM 模組廠營收也隨之下滑，惟該公司及其子公司之主要銷售客戶 G 公司居於 DRAM 模組供應商的領導地位，是少數逆勢成長的公司，向該公司及其子公司採購數量相較去年同期增加，故產生數量有利差異 3,542,855 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 1,629,993 仟元。

(B)營業成本增加 2,681,805 仟元

108 年度因主要銷售客戶 G 公司，致銷售數量增加，產生數量不利差異 2,414,999 仟元，及因當年度整體產能利用率下降，使單位成本上升，產生價格不利差異 205,935 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 60,871 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 108 年度記憶體產品之營業毛利較 107 年度減少 6,283,403 仟元。

B.108 及 109 年度

(A)營業收入減少 2,406,380 仟元

109 年度由於新冠肺炎疫情所衍生各項應用需求互有消長下，致記憶體市況雖至谷底回溫，惟 PC 應用相關成長力道相對持平，且該公司及其子公司為逐漸降低記憶體價格波動過大產生之營運風險，108 年度開始改變銷售產品結構，將部分記憶體產線轉換至邏輯 IC 代工，故記憶體銷售數量相較前一年度略為降低，產生數量不利差異 2,461,751 仟元，而記憶體報價於 109 年度第四季至谷底回升，故產生價格有利差異 78,386 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 23,015 仟元。

(B)營業成本減少 5,012,274 仟元

109 年度因記憶體銷售數量相較前一年度略為降低，產生數量有利差異 3,186,312 仟元，此外，該公司及其子公司 109 年度整體產能利用率提高，使單位成本下降，價格有利差異 2,584,936 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 758,974 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 109 年度記憶體產品(顆)之營業毛利較 108 年度增加 2,605,894 仟元。

C.110 年截至第三季及 109 年截至第三季

(A)營業收入增加 2,395,995 仟元

110 年截至第三季受惠於半導體產業持續熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，全球晶圓代工產能呈現晶片供不應求，該公司及其子公司產能持續滿載，所以公司調整生產產品組合，記憶體產品(顆)銷售數量相較 109 年前三季減少，產生數量不利差異 897,722 仟元，而記憶體報價持續上揚故產生價格有利差異 4,142,457 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 848,740 仟元。

(B)營業成本減少 958,639 仟元

110 年截至第三季因記憶體銷售數量相較前期減少，產生數量有利差異 882,576 仟元，單位成本減少產生價格有利差異 95,664 仟元，價量相乘效果產生組合不利差異 19,600 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司 110 年截至第三季記憶體產品(顆)之營業毛利較 109 年截至第三季增加 3,354,634 仟元。

經評估該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季之主要產品別之營業收入、營業成本與營業毛利之變化情形，及其價量變化情形，尚屬合理，應無重大異常情事。

(五)最近三個會計年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司（包括母子公司間交易事項）與關係人交易之評估

1.與關係人間業務交易往來情形，以評估其有無涉及非常規交易情事，如屬銷貨予關係人者，則再評估授信政策、交易條件、款項收回、所售產品關係人後續投入生產或再銷售之情形及其合理性，如未符一般交易常規，其差異之原因及合理性

(1)個體財務報告

A.關係人之名稱及關係

關係人名稱	公司簡稱	與該公司之關係
力晶科技股份有限公司	力晶	該公司之母公司(109 年 9 月 24 日後為對該公司具重大影響力之公司)
PowerMemory Inc.	PMI	子公司
Maxram Inc.	Maxram	子公司
黃崇仁	—	主要管理階層
蔡國智	—	主要管理階層(109 年 5 月改選後為非關係人)
吳明長	—	主要管理階層
林盈禎	—	主要管理階層
陳瑞隆	—	主要管理階層(109 年 8 月辭任後為非關係人)
謝再居	—	主要管理階層
童貴聰	—	主要管理階層
朱憲國	—	主要管理階層
謝明霖	—	主要管理階層
劉志能	—	主要管理階層
徐震球	—	主要管理階層(109 年 4 月 10 日退休後為非關係人)
黃毓秀	—	實質關係人
邵章榮	—	主要管理階層
施奕強	—	主要管理階層
吳元雄	—	主要管理階層
力旺電子股份有限公司	力旺	實質關係人(力晶公司 107 年 5 月 24 日董監事改選後為非關係人)
力積電子股份有限公司	力積	實質關係人(該公司 107 年 9 月 4 日董監事改選後為非關係人)
優立有限公司	優立	實質關係人(108 年 8 月 14 日起為非關係人)
智安電子股份有限公司	智安	實質關係人(107 年 12 月 24 日董監事改選後為非關係人)
力智電子股份有限公司	力智	實質關係人(107 年 6 月 11 日董監事改選後為非關係人)
力祥半導體股份有限公司	力祥	實質關係人(107 年 6 月 11 日董監事改選後為非關係人)
愛普科技股份有限公司	愛普	實質關係人(該公司 107 年 9 月 4 日董監事改選後為非關係人)

關係人名稱	公司簡稱	與該公司之關係
智旺科技股份有限公司	智旺	實質關係人
智立投資股份有限公司	智立	實質關係人
智豐科技股份有限公司	智豐	實質關係人
台灣光罩股份有限公司	台灣光罩	實質關係人(109 年 9 月 24 日後為非關係人)
財團法人力晶文化基金會	力晶文化基金會	實質關係人
Zentel Japan Corporation	Zentel Japan	實質關係人
力新國際科技股份有限公司	力新	實質關係人
智仁科技開發股份有限公司	智仁	關聯企業(109 年 9 月 24 日後為實質關係人)
力信投資股份有限公司	力信	關聯企業(109 年 9 月 24 日後為對該公司具重大影響力之公司之合併個體)
世仁投資股份有限公司	世仁	關聯企業(109 年 9 月 24 日後為對該公司具重大影響力之公司之合併個體)
智典國際股份有限公司	智典	關聯企業(109 年 9 月 24 日後為對該公司具重大影響力之公司之合併個體)
世成科技股份有限公司	世成	關聯企業(109 年 9 月 24 日後為實質關係人)
智成電子股份有限公司	智成	關聯企業(109 年 9 月 24 日後為實質關係人)
合肥晶合集成電路有限公司	合肥晶合	關聯企業(109 年 9 月 24 日後為非關係人)
力晶積成電子製造股份有限公司職工福利委員會	力積電福委會	實質關係人
宏麗數位創意股份有限公司	宏麗	實質關係人

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告

B.關係人重大交易事項

(A)營業收入及應收款項

營業收入

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智成	—	214	2,899	27,885
智豐	2,662,231	1,605,063	1,472,901	2,606,746
力積	1,287,468	—	—	—
愛普	1,273,085	—	—	—
力祥	274,401	—	—	—
力智	205,702	—	—	—
智安	9,058	—	—	—
優立	160	—	—	—
Zentel Japan	—	51,411	903,134	323,603
合計	5,712,105	1,656,688	2,378,934	2,958,234

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

應收款項

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智豐	127,537	—	151,421	286,012
智安	2,056	—	—	—
優立	(51)	—	—	—
智成	—	—	—	6,066
Zentel Japan	—	49,914	102,073	14,980
合計	129,542	49,914	253,494	307,058

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

a.智成

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智成營業收入金額分別為 0 仟元、214 仟元、2,899 仟元及 27,885 仟元。應收帳款金額分別為 0 仟元、0 仟元、0 仟元及 6,066 仟元。智成主要營業項目為藍牙 IC 設計，與該公司交易之品項僅有 0.055um/IMC 產品，智成該產品為該公司 0.055um/IMC 平台第一個量產產品，具有成熟化該平台的重要功用，故有其交易之必要性。該產品於該公司目前僅銷售給智成，109 及 110 年第三季因藍芽應用平台產品完成，故開始量產，銷售金額成長。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天內付款，其交易條件與收款情形與一般銷售客戶相較，尚無重大異常之情形。

b.智豐

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智豐營業收入金額分別為 2,662,231 仟元、1,605,063 仟元、1,472,901 仟元及 2,606,746 仟元。應收帳款金額分別為 127,537 仟元、0 仟元、151,421 仟元及 286,012 仟元。智豐係為記憶體零組件通路商，主要銷售為標準型記憶體，以 DRAM 為主，經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為 107 年 1 月至 107 年 8 月為月

結 45 天內付款；107 年 8 月至最近年度為月結 60 天內付款，其交易條件與收款情形與一般銷售客戶相較，尚無重大異常之情形。

c.力積

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力積營業收入金額分別為 1,287,468 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。力積主要營業項目為記憶體銷售及 IC 設計，因其主要為設計部分，故相關製造量產需委外廠商，惟考量需客製化之製程部分，該公司是較符合其需求之 DRAM 代工廠商，其交易之必要性尚屬合理。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天內付款，其交易條件與一般銷售客戶相較無異。

d.愛普

該公司 107~109 年度及 110 年第三季愛普營業收入金額分別為 1,273,085 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。愛普主要營業項目為 IC 設計，因其主要為設計部分，故相關製造量產需委外廠商，惟考量需客製化之製程部分，該公司是較符合其需求之 DRAM 代工廠商，其交易之必要性尚屬合理。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天內付款，其交易條件與一般銷售客戶相較無異。

e.力祥

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力祥營業收入金額分別為 274,401 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。力祥主要營業項目為 IC 設計，主要產品為電源 IC 及 mosfet，因光罩成本高，故同一品項僅會向一家晶圓代工下單，惟考量需客製化之製程部分，該公司是較符合其需求廠商，其交易之必要性尚屬合理。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天內付款，其交易條件與一般銷售客戶相較無異。

f.力智

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力智營業收入金額分別為 205,702 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。力智主要營業項目為 IC 設計，主要產品為電源 IC，因光罩成本高，故同一品項僅會向一家晶圓代工下單，惟考量需客製化之製程部分，該公司是較符合其需求廠商，其交易之必要性尚屬合理。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天內付款，其交易條件與一般銷售客戶相較無異。

g.智安

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智安營業收入金額分別為 9,058 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。應收帳款金額分別為 2,056 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。智安主要營業項目為 IC 設計，主要產品為電源 IC，因光罩成本高，故同一品項僅會向一家晶圓代工下單，惟考量需

客製化之製程部分，該公司是較符合其需求廠商，其交易之必要性尚屬合理。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 30 天內付款，其交易條件與一般銷售客戶相較無異。

h.優立

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對優立營業收入金額分別為 160 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。應收帳款金額分別為(51)仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元，107 年度因銷貨折讓，致當年度應收帳款餘額為負數。優立主要營業項目為 IC 設計，因光罩成本高，故同一品項僅會向一家晶圓代工下單，惟考量需客製化之製程部分，該公司是較符合其需求廠商，其交易之必要性尚屬合理。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為預收貨款，其交易條件與收款情形與一般銷售客戶相較，尚無重大異常之情形。

i.Zentel Japan

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對 Zentel Japan 營業收入金額分別為 0 仟元、51,411 仟元、903,134 仟元及 323,603 仟元。應收帳款金額分別為 0 仟元、49,914 仟元、102,073 仟元及 14,980 仟元，Zentel Japan 主要營業項目為記憶體銷售及 IC 設計，因其主要為設計部分，故相關製造量產需委外廠商，惟考量需客製化之製程部分，該公司是較符合其需求之 DRAM 代工廠商。108 年度主係因愛普於第四季將部分業務轉至 Zentel Japan，故於 108 年第四季才開始交易，而 109 年度為完整交易年度，故 109 年度較 108 年度銷售金額成長，110 年度受整體市場需求增加，故銷售金額增加。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件 108 年 1 月至 109 年 8 月為月結 30 天內付款；109 年 9 月至最近年度為開立發票後 30 天內付款，其交易條件與收款情形與一般銷售客戶相較，尚無重大異常之情形。

(B)進貨

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
力晶	—	1,353	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力晶進貨金額分別為 0 仟元、1,353 仟元、0 仟元及 0 仟元。主係因該公司於 108 年 5 月 1 日受讓該公司之母公司力晶 12 吋之營業項目，初期因該公司尚無具毒化物採購之資格，為符合客戶交期，故委由力晶代為採購所致，其交易之必要性尚屬合理。經抽核相關帳冊及交易憑證，交易條件為月結 60 天，其交易條件與付款情形與一般供應商相較，尚無重大異常之情形。

(C)製造費用

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
宏麗	—	—	—	6,359
台灣光罩	168	340	289	—
合計	168	340	289	6,359

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

a.宏麗

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對宏麗製造費用金額分別為 0 仟元、0 仟元、0 仟元及 6,359 仟元，主係該公司向宏麗購買製造部門相關年節禮品，經抽核相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

b.台灣光罩

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對台灣光罩製造費用金額分別為 168 仟元、340 仟元、289 仟元及 0 仟元，主係執行光罩服務及光罩清洗費。因廠內光罩清洗產能不足，故為符合現有製程所使用之光罩，故向台灣光罩交易，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

(D)銷貨成本-權利金

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智成	62,399	18,900	19,653	11,280
力旺	31,045	—	—	—
力祥	306	—	—	—
合計	93,750	18,900	19,653	11,280

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

主係該公司因 IP 製程之技術授權所應支付之權利金，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

(E)推銷費用

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
宏麗	—	—	—	157

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對宏麗推銷費用金額分別為 0 仟元、0 仟元、0 仟元及 157 仟元，主係該公司向宏麗購買銷售部門相關年節禮品，經抽核相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

(F)管理費用

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
力信	206	—	—	—
世仁	310	—	—	—
智仁	12,982	147	95	—
黃崇仁	84	—	—	—
黃毓秀	156	—	—	—
智豐	60	—	—	—
智立	2,520	1,470	—	—
世成	411	434	469	434
力新	79	—	—	—
宏麗	—	—	—	1,396
力晶文化基金會	60,000	—	20,000	—
合計	76,808	2,051	20,564	1,830

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

a.力信及世仁

該公司對力信及世仁之管理費用主係對新屋廠房持份承租之土地租金支出，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

b.智仁

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智仁之管理費用金額分別為 12,982 仟元、147 仟元、95 仟元及 0 仟元，主係向智仁承租台北辦公室及停車位，另因智仁同時為負責處理新屋廠之管理維護，故支付予相關管理維護費。108 年度起向智仁承租台北辦公室及停車位之部分因符合國際會計準則第 16 號租賃，故帳列使用權資產及租賃負債，經抽核核對帳載紀錄、相關憑證及租賃合約，並與鄰近地區之租金行情相較，尚無重大異常情事。

c.黃崇仁及黃毓秀

該公司對黃崇仁及黃毓秀之管理費用主係向其承租台北辦公室停車位之租金支出，108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，故帳列使用權資產及租賃負債，經檢視租賃契約，並與鄰近地區之租金行情相較，尚無重大異常情事。

d.智豐

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智豐之管理費用金額分別為 60 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元，係因高階主管臨時需用公務車，故先向智豐承租，之後並無再繼續承租，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

e.智立

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智立之管理費用金額分別為 2,520 仟元、1,470 仟元、0 仟元及 0 仟元，主係為向智立承租高階主管用車。經檢視租賃契約，並與租賃市場行情相較，尚無重大異常情事。

f.世成

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對世成之管理費用金額分別為 411 仟元、434 仟元、469 仟元及 434 仟元，主係為支付台北辦公室網路管理維護費，經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

g.力新

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力新之管理費用金額分別為 79 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元，力新主要營業項目之一為數位教學平台，故向其支付一年期日語學習平台帳號費用，供員工學習使用，經抽核核對帳載紀錄及相關合約，尚無重大異常情事。

h.宏麗

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對宏麗管理費用金額分別為 0 仟元、0 仟元、0 仟元及 1,396 仟元，主係該公司向宏麗購買管理部門相關年節禮品、銅鑼廠新建工程動土典禮禮品、校園徵才禮品及官方網站維護及雲端主機租賃等費用，經抽核相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

i.力晶文化基金會

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力晶文化基金會之管理費用金額分別為 60,000 仟元、0 仟元、20,000 仟元及 0 仟元，主係捐贈予力晶文化基金會用於提倡藝文等活動相關支出，經抽核核對帳載紀錄及董事會議事錄，尚無重大異常情事。

(G)研發費用

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
宏麗	—	—	—	1,385
PMI	95,337	98,945	87,325	72,440
Maxram	—	—	76,890	88,475
智成	101,661	101,712	39,478	7,000
力旺	474	—	—	—
台灣光罩	2,228	188	—	—
智豐	—	18	—	—
合計	199,700	200,863	203,693	169,300

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

a.宏麗

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對宏麗研發費用金額分別為 0 仟元、0 仟元、0 仟元及 1,385 仟元，主係該公司向宏麗購買研發部門相關年節禮品，經抽核相關帳冊及交易憑證，尚無重大異常之情形。

b.PMI 及 Maxram

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對 PMI 及 Maxram 之研發費用主要為 Flash 產品設計、PDK 製程設計及 DRAM 製程相關設計及研發，經抽核核對帳載紀錄及相關合約，尚無重大異常情事。

c.智成

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智成之研發費用金額分別為 101,661 仟元、101,712 仟元、39,478 仟元及 7,000 仟元。主係其他 IP 廠，無法配合該公司之發展業務需求提供服務，而智成可為該公司的研發產品作客製化，故與其交易。主要研發內容是智成與其共同開發及驗證 AIM 處理器產品技術，並嵌入所需矽智財至力晶的製程平台，開發項目包含工程晶片、矽智財嵌入、產品晶片及軟體開發套件。經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

d.力旺

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力旺之研發費用金額分別為 474 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。主係代工客戶設計的產品需要 OTP IP，力旺之 OTP IP 為目前全世界較大型廠商且經客戶指定，主要研發內容為 90nm 及 110nm 特性及認證資格服務，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

e.台灣光罩

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對台灣光罩之研發費用金額分別為 2,228 仟元、188 仟元、0 仟元及 0 仟元。主要是該公司目前尚在研發階段未量產之產品，因其有光罩需求，故採用台灣光罩之服務，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

f.智豐

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智豐之研發費用金額分別為 0 仟元、18 仟元、0 仟元及 0 仟元。主係為符合智豐之客戶產品所使用之 DRAM，故向智豐交易，其採購專案內容為消費性平台之 ADSL 主控晶片及 IPTV 主控晶片等，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

(H)其他收益及費損

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
力積電福委會	—	—	1,006	—
邵章榮	—	—	—	1
徐震球	—	—	1	—
吳明長	—	—	2	—
林盈禎	—	—	22	17
陳瑞隆	—	—	1	—
謝再居	—	—	3	—
童貴聰	—	—	3	—
朱憲國	—	—	1	—
謝明霖	—	—	1	—
劉志能	—	—	1	—
蔡國智	—	1	—	—
力晶	—	—	1	—
智仁	1,385	441	—	—
智成	23	—	—	—
合肥晶合	87,570	1,196	—	—
施奕強	1	—	—	—
吳元雄	1	—	—	—
力積	240	—	—	—
智安	2,888	—	—	—
智豐	12,469	7,548	7,852	6,713
智旺	192	—	—	—
合計	104,769	9,186	8,894	6,731

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

a.力積電福委會

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力積電福委會之其他收入金額分別為 0 仟元、0 仟元、1,006 仟元及 0 仟元。主要內容為統一超商禮券，該公司向統一超商採購較大量時可以優惠價格購買，再出售力積電福委會，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

b.邵章榮、徐震球、吳明長、林盈禎、陳瑞隆、謝再居、童貴聰、朱憲國、謝明霖、劉志能、蔡國智、施奕強及吳元雄

對該公司之主要管理階層之其他收入主係因公務手機使用年限已至故出售予主要管理階層、員工證件遺失補發及汽車租賃供主要管理階層使用等，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

c.力晶

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力晶之其他收入金額分別為 0 仟元、0 仟元、1 仟元及 0 仟元。主要係舊款筆電使用年限已至，故該公司出售給力晶，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

d.智仁

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智仁之其他收入金額分別為 1,385 仟元、441 仟元、0 仟元及 0 仟元。桃園新屋廠主係做倉庫使用，智仁向其承租倉庫，經檢視租賃契約，並與鄰近地區之租金行情相較，尚無重大異常情事。

e.智成

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智成之其他收入金額分別為 23 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。係董監酬勞收益，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

f.合肥晶合

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對合肥晶合之其他收入金額分別為 87,570 仟元、1,196 仟元、0 仟元及 0 仟元。107 年度主係因合肥晶合營運初期協助提供相關產品之開發及服務收入；於 108 年度因合肥晶合自行生產及開發能力較穩定，故金額相對減少。經抽核核對帳載紀錄及相關合約及憑證，尚無重大異常情事。

g.力積

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對力積之其他收入金額分別為 240 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元。主要為協助力積有關生產資訊處理等服務收入。經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

h.智安及智旺

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智安及智旺之其他收入主要是出租辦公室、停車位租金及押金設算息等其他收入。經檢視租賃契約，並與鄰近地區之租金行情相較，尚無重大異常情事。

i.智豐

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智豐之其他收入金額分別為 12,469 仟元、7,548 仟元、7,852 仟元及 6,713 仟元。主要是該公司提供晶圓產品售後加工服務收入，包含但不限於後段封測產品工程及品質管理等服務。經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

(I)出售存貨及設備維修備品

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
合肥晶合	126	—	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之個體財務報告；該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對合肥晶合出售存貨及設備維修備品金額分別為 126 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元，主係因力晶係技術授權予合肥晶合，故於合肥晶合營運初期協助提供相關產品之檢驗，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

(J)其他應收款

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
合肥晶合	61,645	—	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對合肥晶合之其他應收款金額分別為 61,645 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元，主係因合肥晶合營運初期協助提供相關產品之開發及服務收入，經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

(K)其他應付款

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智豐	—	—	2,900	—
黃崇仁	—	2,201	—	—
力信	1,940	—	—	—
智典	2,359	—	—	—
智成	133,149	114,988	9,278	3,585
智仁	459	—	324	—
台灣光罩	327	84	—	—
合計	138,234	117,273	12,502	3,585

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

a.智豐、力信及智典

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智豐、力信及智典之其他應付款主係向其借款之應付利息，經抽核核對帳載紀錄及相關付款憑證，尚無重大異常情事。

b.黃崇仁

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對黃崇仁之其他應付款金額分別為 0 仟元、2,201 仟元、0 仟元及 0 仟元。主要是國外出差之差旅費，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

c.智成

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智成之其他應付款金額分別為 133,149 仟元、114,988 仟元、9,278 仟元及 3,585 仟元。主要是支付權利金及研發費用，經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

d.智仁

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智仁之其他應付款金額分別為 459 仟元、0 仟元、324 仟元及 0 仟元。主要是台北辦公室之雜項分攤費用，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

e.台灣光罩

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對台灣光罩之其他應付款金額分別為 327 仟元、84 仟元、0 仟元及 0 仟元。主要是支付製造費用及研發費用，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

(L)合約負債

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
合肥晶合	59,970	—	—	—
智豐	—	—	20,391	—
優立	235	—	—	—
合計	60,205	—	20,391	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

a.合肥晶合

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對合肥晶合之合約負債金額分別為 59,970 仟元、0 仟元、0 仟元及 0 仟元，主係 90nm 項目技術合作開發因收款時程與專案進度時程差異所導致之合約負債，經抽核核對帳載紀錄及相關合約，尚無重大異常情事。

b.智豐及優立

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對智豐及優立之合約負債主係銷貨收入之預收貨款，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

(M)取得不動產、廠房及設備

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智豐	—	—	1,000,000	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年第三季向智豐取得不動產、廠房及設備之金額分別為 0 仟元、0 仟元、1,000,000 仟元及 0 仟元，主係因配合生產製程計劃及資金規劃，故向智豐買回 consign 設備一批，供晶圓產品生產製造使用，經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

(N)取得使用權資產

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智立	—	4,946	—	2,500

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年第三季向智立取得使用權資產之金額分別為 0 仟元、4,946 仟元、0 仟元及 2,500 仟元，主係向智立承租高階主管公務用車，經檢視租賃契約，並與租賃市場行情相較，尚無重大異常情事。

(O)存入保證金

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智仁	220	—	—	—
智成	6	—	—	—
智旺	2	—	—	—
智安	412	—	—	—
合計	640	—	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對關係人之存入保證金主係出租新屋廠房及辦公室、及其門禁卡押金等，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

(P)存出保證金

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
黃崇仁	1	1	1	1
黃毓秀	1	1	1	1
合計	2	2	2	2

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

該公司 107~109 年度及 110 年第三季對關係人之存出保證金主係承租台北辦公室停車位之押金，經檢視租賃合約，核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

(Q)承租協議

租金支出

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
力信	206	—	—	—
世仁	310	—	—	—
智仁	12,328	—	—	—
黃崇仁	84	—	—	—
黃毓秀	156	—	—	—

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智豐	60	—	—	—
智立	2,520	—	—	—
合計	15,664	—	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

註：108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，故不再認列租金支出，改為使用權資產之折舊費用及財務成本。

租賃負債-流動

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
黃崇仁	80	81	82
智仁	6,911	12,100	11,863
黃毓秀	148	151	151
智立	2,471	1,463	2,086
合計	9,610	13,795	14,182

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

註：108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，將未來支付義務認列為租賃負債。

租賃負債-非流動

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
黃崇仁	245	165	97
智仁	21,100	24,525	14,974
黃毓秀	455	306	180
智立	1,461	—	—
合計	23,261	24,996	15,251

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

註：108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，將未來支付義務認列為租賃負債。

財務成本-租賃負債

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
黃崇仁	9	5	3
智仁	840	733	391
力信	23	—	—
世仁	35	—	—
黃毓秀	16	9	5
智立	35	42	14
合計	958	789	413

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

註：108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，就租賃負債採有效利息法攤銷，並認列財務成本。

a.力信及世仁

該公司對力信及世仁之租金支出及財務成本主係對新屋廠房持份承租之土地相關費用，經核對帳載紀錄，評估尚無重大異常之情事。

b.智仁

該公司對智仁之租金支出、租賃負債及其財務成本主係因向其承租台北辦公室及停車位，經檢視租賃契約，並與鄰近地區之租金行情相較，尚無重大異常情事。

c.黃崇仁及黃毓秀

該公司對黃崇仁及黃毓秀之租金支出、租賃負債及其財務成本主係因向其承租台北辦公室停車位，經檢視租賃契約，並與鄰近地區之租金行情相較，尚無重大異常情事。

d.智立

該公司對智立之租金支出、租賃負債及其財務成本主係為向智立承租高階主管用車，經檢視租賃契約，並與租賃市場行情相較，尚無重大異常情事。

(R)向關係人借款

借款-帳列(長)短期借款

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智典	100,000	—	—	—
力信	389,435	—	—	—
智豐	—	—	735,000	—
合計	489,435	—	735,000	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

財務成本-借款

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智典	3,469	7	—	—
力信	13,402	1,634	—	—
智豐	—	—	9,533	7,068
合計	16,871	1,641	9,533	7,068

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之個體財務報告；該公司提供。

a.智典及力信

該公司因短期營運資金週轉需求向智典及力信借款，其財務成本以年利率 2.5%計算，且分別已於 108 年 1 月 2 日及 108 年 4 月 10 日還款

完畢，經抽核會計傳票、借款合約及相關付款憑證，尚無重大異常之情事。

b.智豐

該公司之向智豐借款主係向智豐買回 consign 機台 1,000,000 仟元，已於 109 年 4 月 20 日支付頭款 300,000 仟元，尾款 700,000 仟元轉為借款，含稅金額為 735,000 仟元，其財務成本以年利率 1.8%計算，業已於 110 年 7 月 15 日還款完畢，經抽核會計傳票、借款合約及相關付款憑證，尚無重大異常之情事。

(2)合併財務報告

A.關係人之名稱及關係

關係人名稱	公司簡稱	與該公司之關係
Powerchip Corporation Japan	Powerchip Japan	實質關係人

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告。

註:僅揭示未於經會計師查核簽證之個體財務報告揭露之關係人名稱，其他關係人名稱請詳前述(1)個體財務報告 A.關係人之名稱及關係。

B.關係人重大交易事項

(A)營業收入及應收款項

營業收入

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智成	—	214	2,899	27,885
智豐	2,662,231	1,605,063	1,472,901	2,606,746
力積	1,287,468	—	—	—
愛普	1,273,085	—	—	—
力祥	274,401	—	—	—
力智	205,702	—	—	—
智安	9,058	—	—	—
優立	160	—	—	—
Zentel Japan	—	51,411	903,134	323,603
合計	5,712,105	1,656,688	2,378,934	2,958,234

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

應收款項

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智豐	127,537	—	151,421	286,012
智安	2,056	—	—	—
優立	(51)	—	—	—
智成	—	—	—	6,066
Zentel Japan	—	49,914	102,073	14,980
合計	129,542	49,914	253,494	307,058

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告之關係人銷貨交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(A)營業收入及應收款項」。

(B)進貨

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
力晶	—	1,353	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告之關係人進貨交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(B)進貨」。

(C)製造費用

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
宏麗	—	—	—	6,359
台灣光罩	168	340	289	—
合計	168	340	289	6,359

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之製造費用交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(C)製造費用」。

(D)銷貨成本-權利金

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智成	62,399	18,900	19,653	11,280
力旺	31,045	—	—	—
力祥	306	—	—	—
合計	93,750	18,900	19,653	11,280

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之權利金交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(D)銷貨成本-權利金」。

(E)推銷費用

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
宏麗	—	—	—	157

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之推銷費用交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(E)推銷費用」。

(F)管理費用

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
力信	206	—	—	—
世仁	310	—	—	—
智仁	12,982	147	95	—
黃崇仁	84	—	—	—
黃毓秀	156	—	—	—
智豐	60	—	—	—
智立	2,520	1,470	—	—
世成	411	434	469	434
力新	79	—	—	—
宏麗	—	—	—	1,396
Powerchip Japan	3,759	4,398	4,548	3,349
Zentel Japan	—	—	29	—
力晶文化基金會	60,000	—	20,000	—
合計	80,567	6,449	25,141	5,179

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

a.Powerchip Japan

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第三季對 Powerchip Japan 管理費用之金額分別為 3,759 仟元、4,398 仟元、4,548 仟元及 3,349 仟元，主要係該公司之子公司 PMI 及 Maxram 向 Powerchip Japan 承租辦公室，經檢視租賃契約，並與鄰近地區之租金行情相較，尚無重大異常情事。

b.Zentel Japan

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第三季對 Zentel Japan 管理費用之金額分別為 0 仟元、0 仟元、29 仟元及 0 仟元，主要係 Zentel Japan 該部門人員參與該公司之子公司 Maxram 的 DRAM 研發過程，因 Maxram 考量仍有相關研發需求，故向 Zentel Japan 購買八王子該部門固定資產之衍生相關費用，經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之管理費用交易除上述外，其餘同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(F)管理費用」。

(G)研發費用

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
宏麗	—	—	—	1,385
智成	101,661	101,712	39,478	7,000
力旺	474	—	—	—
台灣光罩	2,228	188	—	—
智豐	—	18	—	—
合計	104,363	101,918	39,478	8,385

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之研發費用交易，除該公司與 PMI 及 Maxram 之研發費用業已於編製合併財務報告時沖銷，其餘同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(G)研發費用」。

(H)其他收益及費損

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
力積電 福委會	—	—	1,006	—
邵章榮	—	—	—	1
徐震球	—	—	1	—
吳明長	—	—	2	—
林盈禎	—	—	22	17
陳瑞隆	—	—	1	—
謝再居	—	—	3	—
童貴聰	—	—	3	—
朱憲國	—	—	1	—
謝明霖	—	—	1	—
劉志能	—	—	1	—
蔡國智	—	1	—	—
力晶	—	—	1	—
智仁	1,385	441	—	—
智成	23	—	—	—
合肥晶合	87,570	1,196	—	—
施奕強	1	—	—	—
吳元雄	1	—	—	—
力積	240	—	—	—
智安	2,888	—	—	—
智豐	12,469	7,548	7,852	6,713
智旺	192	—	—	—
合計	104,769	9,186	8,894	6,731

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之其他收益及廢損交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(H)其他收益及廢損」。

(I)出售存貨及設備維修備品

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
合肥晶合	126	—	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中出售存貨及設備維修備品予關係人同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(I)出售存貨及設備維修備品」。

(J)其他應收款

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
合肥晶合	61,645	—	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之其他應收款交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(J)其他應收款」。

(K)其他應付款

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智豐	—	—	2,900	—
黃崇仁	—	2,201	—	—
力信	1,940	—	—	—
智典	2,359	—	—	—
智成	133,149	114,988	9,278	3,585
智仁	459	—	324	—
台灣光罩	327	84	—	—
合計	138,234	117,273	12,502	3,585

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之其他應付款交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(K)其他應付款」。

(L)合約負債

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
合肥晶合	59,970	—	—	—
智豐	—	—	20,391	—
優立	235	—	—	—
合計	60,205	—	20,391	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之合約負債交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(L)合約負債」。

(M)取得不動產、廠房及設備

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智豐	—	—	1,000,000	—
Zentel Japan	—	—	1,080	—
合計	—	—	1,001,080	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

a.Zentel Japan

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第三季向 Zentel Japan 取得不動產、廠房及設備之金額分別為 0 仟元、0 仟元、1,080 仟元及 0 仟元，主要係 Zentel Japan 該部門人員參與該公司之子公司 Maxram 的 DRAM 研發過程，因 Maxram 考量仍有相關研發需求，故向 Zentel Japan 購買八王子該部門之固定資產，經抽核核對帳載紀錄及相關憑證，尚無重大異常情事。

該公司及其子公司合併財務報告中向關係人取得不動產、廠房及設備交易除上述外，其餘同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(M)取得不動產、廠房及設備」。

(N)取得使用權資產

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智立	—	4,946	—	2,500

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中向關係人取得使用權資產交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(N)取得使用權資產」。

(O)存入保證金

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智仁	220	—	—	—
智成	6	—	—	—
智旺	2	—	—	—
智安	412	—	—	—
合計	640	—	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之存入保證金交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(O)存入保證金」。

(P)存出保證金

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
黃崇仁	1	1	1	1
黃毓秀	1	1	1	1
合計	2	2	2	2

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中與關係人之存出保證金交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(P)存出保證金」。

(Q)承租協議

租金支出

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
力信	206	—	—	—
世仁	310	—	—	—
智仁	12,328	—	—	—
黃崇仁	84	—	—	—
黃毓秀	156	—	—	—
智豐	60	—	—	—
Powerchip Japan	3,759	—	—	—
智立	2,520	—	—	—
合計	19.423	—	—	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

註：108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，故不再認列租金支出，改為使用權資產之折舊費用及財務成本。

租賃負債-流動

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
黃崇仁	80	81	82
智仁	6,911	12,100	11,863
黃毓秀	148	151	151
智立	2,471	1,463	2,086
合計	9,610	13,795	14,182

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

註：108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，將未來支付義務認列為租賃負債。

租賃負債-非流動

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
黃崇仁	245	165	97
智仁	21,100	24,525	14,974
黃毓秀	455	306	180
智立	1,461	—	—
合計	23,261	24,996	15,251

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

註：108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，將未來支付義務認列為租賃負債。

財務成本-租賃負債

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
黃崇仁	9	5	3
智仁	840	733	391
力信	23	—	—
世仁	35	—	—
黃毓秀	16	9	5
智立	35	42	14
合計	958	789	413

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

註：108 年度起因符合國際會計準則第 16 號租賃之適用情形，就租賃負債採有效利息法攤銷，並認列財務成本。

該公司及其子公司合併財務報告之關係人承租協議中，該公司之子公司向 Powerchip Japn 承租辦公室，請詳前述「(2)合併財務報告；B.關係人重大交易事項；(F)管理費用」，除上述外，其餘同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(Q)承租協議」。

(R)向關係人借款

借款-帳列(長)短期借款

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智典	100,000	—	—	—
力信	389,435	—	—	—
智豐	—	—	735,000	—
合計	489,435	—	735,000	—

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

財務成本-借款

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年 截至第三季
智典	3,469	7	—	—
力信	13,402	1,634	—	—
智豐	—	—	9,533	7,068
合計	16,871	1,641	9,533	7,068

資料來源：該公司各期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；該公司提供。

該公司及其子公司合併財務報告中向關係人借款交易同個體財務報告之內容，請詳前述「(1)個體財務報告；B.關係人重大交易事項；(R)向關係人借款」。

2.發行人與同屬關係企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入百分之三十以上者)，有無相互競爭之情形

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，其同屬關係企業公司共 8 家企業公司，茲將該公司與同屬關係企業公司之主要業務或主要商品列示如下，並說明有無相互競爭之情形：

A.該公司之母公司及其子公司(不含該公司及其子公司)

經查詢力晶科技 108 及 109 年度經會計師查核簽證財務報告、經濟部商工登記公示資料，其主要經營業務項目列示如下：

關係企業名稱	主要營運項目	有無相互競爭
力晶科技	108 年 5 月力晶科技將旗下的 12 吋晶圓代工相關營業、資產讓與予該公司及其子公司，轉為控股公司。	無
世仁投資	各項投資業務	無
力信投資	各項投資業務	無
富碩投資	各項投資業務	無
智典公司	藝術品買賣等業務	無

力晶科技原所營項目為 12 吋晶圓代工業務，108 年 5 月力晶科技將旗下的 12 吋晶圓代工相關營業、資產讓與予該公司及其子公司，轉為控股公司。其旗下之子公司世仁投資、力信投資及智典公司均為投資公司，智典公司主要所營項目為藝術品買賣等業務。該公司與上述關係企業所營業務並不相同，故應無相互競爭之疑慮。

B.該公司之子公司

關係企業名稱	主要營運項目	有無相互競爭
Global Powertec	投資控股公司	無
PowerMemory	Flash 製程相關設計及研發	無
Maxram	DRAM 製程相關設計及研發	無

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司屬半導體產業，主要從事邏輯暨特殊應用產品之晶圓代工服務及記憶體產品之晶圓代工服務。上表關係企業中，該公司透過境外設立投資控股公司 Global Powertec，轉投資二家日本公司 PowerMemory 及 Maxram，主係為配合力積電營運需求，從事研發專案以賺取技術服務收入，主要營業項目分別為 Flash 及 DRAM 製程相關設計及研發。該公司對所有轉投資事業之財務業務具有完全之控制能力，且該公司及其轉投資事業之業務運作係由該公司統籌規劃集團資源之運用與分工，就企業型態而言，並無相互競爭情形。

綜上所述，該公司與上述 8 家關係企業公司之主要業務或產品並無相互競爭之情形。

二、財務狀況

(一)發行人最近期及最近三個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況及財務比率，並作變動分析與同業比較

1.選擇採樣公司之理由

該公司及其子公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工(顯示驅動 IC 產品、電源管理晶片產品、分離式元件產品、CMOS 影像感測器產品、嵌入式非揮發記憶體產品之晶圓代工服務)；以及記憶體產品晶圓代工(動態隨機存取記憶體產品、快閃記憶體產品之晶圓代工服務)。

經檢視其相關產業及同業資料，上市公司聯電以 12 吋晶圓代工服務及 8 吋晶圓代工服務為主；上櫃公司世界係 8 吋晶圓代工服務為主；上市公司華邦電主要以 12 吋晶圓廠產製動態隨機存取記憶體及快閃記憶體產品，另透過其子公司新唐科技，提供 6 吋晶圓代工服務。經綜合考量國內上市及上櫃公司之營業項目、產業特性及資本額等因素，選取聯電、世界及華邦電做為採樣公司。

此外，參考財團法人金融聯合徵信中心編印之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」中所列「C26 電子零組件製造業」之財務比率作為同業平均之財務比率依據。

公司名稱	代號	主要營業項目	產能	銷售比重
力積電	6770	提供半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工以及記憶體產品晶圓代工。	109 年產能： 8 吋廠 2 座：900 仟片 12 吋廠 3 座：1,260 仟片	109 年度：56%邏輯產品；44%記憶體產品
聯　電	2303	積體電路各種半導體相關零組件。	109 年產能： 6 吋廠 1 座：371 仟片。 8 吋廠 7 座：3,853 仟片。 12 吋廠 4 座:2,281 仟片。	100%邏輯產品
世　界	5347	依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。 提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。 提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。	109 年產能： 8 吋廠 4 座，3 座於臺灣，1 座於新加坡：約 2,900 仟片。	100%邏輯產品
華邦電	2344	積體電路；半導體記憶零組件及其系統產品；電腦系統用、數位通訊用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品；其他半導體零組件；電腦軟體程式設計及資料處理；兼營與業務相關之進出口貿易業務。	109 年度年產能： 12 吋(記憶體)：666 仟片 6 吋(邏輯)：692 仟片	109 年度：66%記憶體產品；34%邏輯產品。

資料來源：公開資訊觀測站、各公司年報，各公司網站、法說會簡報資料。

2.最近期及最近三個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況

單位：新臺幣仟元

項目	年度 / 公司	107年度	108年度			109年度			110年截至第三季		
		金額	金額	註1	註2(%)	金額	註1	註2(%)	金額	註1	註2(%)
營業收入	力積電	49,913,779	35,897,121	(14,016,658)	(28.08)	45,684,615	9,787,494	27.27	45,865,144	12,053,871	35.65
	聯　電	151,252,571	148,201,641	(3,050,930)	(2.02)	176,820,914	28,619,273	19.31	註 3	註 3	註 3
	世　界	28,928,094	28,286,072	(642,022)	(2.22)	33,131,202	4,845,130	17.13	註3	註 3	註 3
	華邦電	51,190,323	48,771,434	(2,418,889)	(4.73)	60,683,171	11,911,737	24.42	註 3	註 3	註 3
營業成本	力積電	34,633,514	32,896,453	(1,737,061)	(5.02)	34,692,204	1,795,751	5.46	27,852,105	1,976,969	7.64
	聯　電	128,412,544	126,886,669	(1,525,875)	(1.19)	137,823,813	10,937,144	8.62	註 3	註 3	註 3
	世　界	18,759,824	17,953,285	(806,539)	(4.30)	21,874,918	3,921,633	21.84	註 3	註 3	註 3
	華邦電	32,039,220	35,857,582	3,818,362	11.92	43,643,035	7,785,453	21.71	註 3	註 3	註 3
營業毛利	力積電	15,280,265	3,000,668	(12,279,597)	(80.36)	10,992,411	7,991,743	266.33	18,013,039	10,076,902	126.97
	聯　電	22,840,027	21,314,972	(1,525,055)	(6.68)	38,997,101	17,682,129	82.96	註 3	註 3	註 3
	世　界	10,168,270	10,332,787	164,517	1.62	11,256,284	923,497	8.94	註 3	註 3	註 3
	華邦電	19,151,103	12,913,852	(6,237,251)	(32.57)	17,040,136	4,126,284	31.95	註 3	註 3	註 3
營業費用	力積電	6,651,675	5,272,132	(1,379,543)	(20.74)	5,460,494	188,362	3.57	5,685,498	1,685,104	42.12
	聯　電	22,159,679	21,807,284	(352,395)	(1.59)	23,243,584	1,436,300	6.59	註 3	註 3	註 3
	世　界	3,013,562	3,423,398	409,836	13.60	3,840,078	416,680	12.17	註 3	註 3	註 3
	華邦電	11,224,406	11,658,643	434,237	3.87	15,412,845	3,754,202	32.20	註 3	註 3	註 3
營業(損)益	力積電	8,886,597	(2,098,779)	(10,985,376)	(123.62)	5,744,244	7,843,023	373.69	12,551,292	8,505,925	210.26
	聯　電	5,797,232	4,689,850	(1,107,382)	(19.10)	22,007,407	17,317,557	369.26	註 3	註 3	註 3
	世　界	7,154,708	6,909,389	(245,319)	(3.43)	7,416,206	506,817	7.34	註 3	註 3	註 3
	華邦電	7,926,697	1,255,209	(6,671,488)	(84.16)	1,627,291	372,082	29.64	註 3	註 3	註 3
營業	力積電	(246,549)	(516,106)	(269,557)	(109.33)	(945,171)	(429,065)	(83.14)	(720,096)	(102,857)	(16.66)

單位：新臺幣仟元

項目	年度 / 公司	107年度	108年度			109年度			110年截至第三季		
		金額	金額	註1	註2(%)	金額	註1	註2(%)	金額	註1	註2(%)
外收入及支出	聯　電	(3,612,833)	1,045,787	4,658,620	128.95	5,918,772	4,872,985	465.96	註 3	註 3	註 3
	世　界	317,478	448,930	131,452	41.41	151,001	(297,929)	(66.36)	註 3	註 3	註 3
	華邦電	468,203	497,308	29,105	6.22	185,117	(312,191)	(62.78)	註 3	註 3	註 3
本期淨利(損)	力積電	6,914,744	(2,643,184)	(9,557,928)	(138.23)	3,806,477	6,449,661	244.01	9,891,995	7,168,345	263.19
	聯　電	2,643,052	6,128,767	3,485,715	131.88	27,180,412	21,051,645	343.49	註 3	註 3	註 3
	世　界	6,166,269	5,860,497	(305,772)	(4.96)	6,305,520	445,023	7.59	註 3	註 3	註 3
	華邦電	7,727,658	1,477,287	(6,250,371)	(80.88)	1,519,043	41,756	2.83	註 3	註 3	註 3
本期其他綜合損益	力積電	(12,043)	(111,219)	(99,176)	823.52	(86,850)	24,369	21.91	(2,899)	(2,757)	(1,941.55)
	聯　電	949,944	3,408,785	2,458,841	258.84	4,685,534	1,276,749	37.45	註 3	註 3	註 3
	世　界	284,652	(539,802)	(824,454)	(289.64)	(1,035,606)	(495,804)	(91.85)	註 3	註 3	註 3
	華邦電	(1,738,472)	1,294,756	3,033,228	174.48	3,291,251	1,996,495	154.20	註 3	註 3	註 3
本期綜合損益總額	力積電	6,902,701	(2,754,403)	(9,657,104)	(139.90)	3,719,627	6,474,030	235.04	9,889,096	7,165,588	263.10
	聯　電	3,592,996	9,537,552	5,944,556	165.45	31,865,946	22,328,394	234.11	註 3	註 3	註 3
	世　界	6,450,921	5,320,695	(1,130,226)	(17.52)	5,269,914	(50,781)	(0.95)	註 3	註 3	註 3
	華邦電	5,989,186	2,772,043	(3,217,143)	(53.72)	4,810,294	2,038,251	73.53	註 3	註 3	註 3

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告。
註 1：較前一年度相同期間之增減金額。
註 2：較前一年度相同期間之增減比率。
註 3：截至刊印日止，同業尚未公告第三季財務報告。

3.變動分析及同業比較

(1)營業收入、營業成本、營業毛利及營業(損)益

請參閱本評估報告參、一、(四)業績概況之說明。

(2)營業費用變化原因及合理性

單位：新臺幣仟元；%

項目 / 年度	107 年度		108 年度		109 年度		110 年截至第三季	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
推銷費用	461,925	0.93	300,790	0.84	335,218	0.73	370,006	0.81
管理費用	2,736,267	5.48	2,008,972	5.60	1,890,511	4.14	2,363,702	5.15
研究發展費用	3,453,483	6.92	2,962,370	8.25	3,234,765	7.08	2,951,790	6.44
營業費用	6,651,675	13.33	5,272,132	14.69	5,460,494	11.95	5,685,498	12.40
其他收益及費損淨額	258,007	0.52	172,685	0.48	212,327	0.46	223,751	0.49
營業利益	8,886,597	17.80	(2,098,779)	(5.85)	5,744,244	12.57	12,551,292	27.37

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司之營業費用包括推銷費用、管理費用及研究發展費用，107~109 年度及 110 年截至第三季之營業費用分別為 6,651,675 仟元、5,272,132 仟元、5,460,494 仟元及 5,685,498 仟元，占營收比重分別為 13.33%、14.69%、11.95%及 12.40%，茲就營業費用之主要項目分別說明如下：

A.推銷費用

推銷費用主要係為業務人員之薪資及相關費用、園區管理費、間接材料及折舊費用等，108 年度推銷費用相較 107 年度減少 161,135 仟元，主要係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金及員工酬勞等帳列薪資費用減少

128,315 仟元，及園區管理費減少 29,359 仟元。109 年推銷費用增加 34,428 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 17,530 仟元且因營收成長致園區管理費增加 18,236 仟元所致。110 年截至第三季推銷費用相較去年同期增加 123,223 仟元，主係因業績成長、調薪及人員增加，致獎金及員工認股權帳列之薪資費用增加 43,456 仟元，員工酬勞增加 39,761 仟元；園區管理費增加 23,121 仟元。

B.管理費用

管理費用主要係間接人員之薪資費用、折舊費用、環保費用、電腦使用費及專業服務費(勞務費)等，108 年度管理費用減少 727,295 仟元，主係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 107 年度減少 277,427 仟元，及員工酬勞減少 410,830 仟元。109 年度管理費用減少 118,461 仟元，主係竹南廠於 108 年 5 月前屬建廠期間，期間費用 318,118 仟元帳列管理費用，108 年 6 月起帳列製造費用，故 109 年管理費用減少。排除竹南廠建廠費用後，管理費用增加 199,657 仟元，主係獎金及員工酬勞增加。110 年截至第三季管理費用相較去年同期增加 988,334 仟元，主係業績成長、調薪及銅鑼廠建廠人員增加，致獎金及員工認股權帳列之薪資費用增加 364,245 仟元，員工及董監酬勞增加 563,091 仟元，租金費用較前期增加 21,505 仟元，主係因公司銅鑼廠建廠所需短期租用銅鑼園區土地以作為土方暫存放置之用，致費用增加。

C.研究發展費用

研究發展費用主要為研發人員之薪資費用、專業服務費、電腦使用費、製程及技術改善費用、折舊費用、光罩費用及間接材料等，108 年度研究發展費用減少 491,113 仟元，主係 108 年度營收減少及稅前呈現虧損，故各項獎金等帳列薪資費用相較 107 年度減少 516,765 仟元。109 年研究發展費用增加 272,395 仟元，主係因業績成長由虧轉盈，獎金、員工酬勞及員工認股權帳列之薪資費用增加 288,095 仟元所致。110 年截至第三季研究發展費用相較去年同期增加 573,547 仟元，主係因業績成長、調薪及人員增加，致獎金及員工認股權帳列之薪資費用增加 202,671 仟元，員工酬勞增加 320,647 仟元。因新增研發設備，折舊費用增加 60,226 仟元，因配合研發專案發生時程，專業服務費減少 80,264 仟元，製程及技術改善增加 28,502 仟元，光罩減少 21,241 仟元。

D.其他收益及費損淨額

其他收益及費損淨額主要為賠償收入、客戶產品開發服務收入、處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益(損失)、原物料零配件轉售收入、光罩代買收入、維修收入等。107 年度其他收益及費損淨額 258,007 仟元主要係客戶產品開發服務收入；108 年度其他收益及費損淨額 172,685 仟元，主係 8A 廠因電力中斷意外事故造成財產損失及營業中斷損失之保險理賠收入；109 年度其他收益

及費損淨額 212,327 仟元主要係客戶產品開發服務收入與處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益；110 年截至第三季其他收益及費損淨額 223,751 仟元主要係處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益、原物料零配件轉售淨收入、維修收入、開發收入、光罩代買收入等。

綜上所述，該公司 107~109 年度及 110 年截至第三季營業費用之變動情形，尚無重大異常情事。

(3)營業外收支

該公司及其子公司之營業外收入及支出包括其他收入、其他利益及損失及財務成本，107~109 年度及 110 年截至第三季之營業外收入及支出分別為(246,549)仟元、(516,106)仟元、(945,171)仟元及(720,096)仟元，占營收比重分別為(0.49)%、(1.44)%、(2.07)%及(1.57)%，茲就營業外收入及支出之主要項目分別說明如下：

A.其他收入

該公司及其子公司業外之其他收入主係利息收入及股利收入，而以利息收入為主，107~109 年度及 110 年截至第三季之利息收入 91,954 仟元、62,543 仟元、27,977 仟元及 22,128 仟元，主要係隨各年度銀行活期存款及定期存款產生之利息收入變動所致。

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度		107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
		金額	金額	金額	金額
其他收入	利息收入	91,954	62,543	27,977	22,128
	股利收入	610	-	-	-
	小計	92,564	62,543	27,977	22,128
其他利益及損失	外幣兌換淨(損失)利益	166,282	(68,070)	(316,469)	(191,342)
	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(損失)利益	(39,512)	12,784	21,504	(23,987)
	小計	126,770	(55,286)	(294,965)	(215,329)
財務成本	借款之利息	(405,859)	(437,244)	(479,135)	(350,671)
	租賃負債之利息	-	(75,849)	(189,059)	(168,773)
	應付租賃款之利息	(49,562)	-	-	-
	其他	(10,462)	(10,270)	(9,989)	(7,451)
	小計	(465,883)	(523,363)	(678,183)	(526,895)
合計		(246,549)	(516,106)	(945,171)	(720,096)

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

B.其他利益及損失

該公司及其子公司業外之其他利益及損失主係外幣兌換損益及透過損益按公允價值衡量之金融資產利益(損失)，變動說明如下：

(A)外幣兌換淨(損失)利益

該公司及其子公司於 107~109 年度及 110 年截至第三季之兌換利益(損失)淨額分別為 166,282 仟元、(68,070)仟元、(316,469)仟元及(191,342)仟元，占營業收入之比率分別為 0.33%、(0.19%)、(0.69%)及(0.42%)，占營業淨利(損失)之比率則分別為 1.87%、(3.24%)、(5.51%)及(1.52%)；該公司及其子公司產生之兌換損益主要係美元銷貨所產生。107 年度美國國內經濟增長強勁、聯準會持續升息，致美元平穩升值，進而產生淨兌換利益；108 年度受到美國聯準會三度降息之影響，致美元貶值，進而產生淨兌換損失；109 年度受到新冠肺炎疫情影響，對經濟產生巨大的衝擊，美國貨幣政策因此轉向寬鬆，且是無限量化寬鬆，致美元持續貶值，對於持有美元淨資產部位不利，因此持續產生兌換損失；110 年截至第三季大抵美元仍呈現貶值走勢，惟其兌換損失占營業收入比例已約略降至 0.42%。該公司及其子公司除透過主要往來銀行提供專業諮詢的服務，以掌握匯率走勢外，主係透過即期交易及遠期外匯合約來規避以非新臺幣計價之貨幣性資產與負債及高度可能發生之預期交易所產生之匯率風險，故匯率波動應不致於對該公司之財務業務產生重大影響。

(B)透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(損失)利益

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季之透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨(損失)利益分別為(39,512)仟元、12,784 仟元、21,504 仟元及(23,987)仟元，即是承作遠期外匯合約之已實現損益和期末評價所產生之未實現損益合計。

C.財務成本

該公司及其子公司業外之財務成本主係借款利息費用及租賃負債利息，主以借款利息費用為主，107~109 年度及 110 年截至第三季之借款利息費用分別為(405,859)仟元、(437,244)仟元、(479,135)仟元及(350,671)仟元，主要係隨各年度銀行借款產生之利息費用變動所致。

(4)稅前純益及稅後純益變化原因及其合理性分析

單位：新臺幣仟元；%

項目＼年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
	金額	金額	金額	金額
稅前淨利	8,640,048	(2,614,885)	4,799,073	11,831,196
所得稅費用	(1,725,304)	(28,299)	(992,596)	(1,939,201)
本期淨利	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477	9,891,995
加權平均流通在外股數	2,705,197	2,821,863	3,105,197	3,221,863
基本每股盈餘(元)	2.56	(0.94)	1.23	3.07

資料來源：各年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年截至第三季之稅前淨利分別為 8,640,048 仟元、(2,614,885)仟元、4,799,073 仟元及 11,831,196 仟元；每股盈餘(虧損)分別為 2.56 元、(0.94)元、1.23 元及 3.07 元。該公司及其子公司 108 年度

稅前虧損主係108年度半導體產業呈現衰退趨勢致整體訂單減少、單位售價(ASP)下跌，整體產能使用率下降，使得產品之單位成本上升，導致營業毛利及毛利率下降。109年度營業毛利較108年度增加7,991,743仟元，成長幅度達266.33%，主要受惠於終端市場的需求使訂單增加，產能利用率提升、單位售價(ASP)回升及持續推進製程技術所致。110 年截至第三季營業毛利較去年同期增加10,076,902仟元，成長幅度126.97%，主係受惠產能利用率滿載、持續推進製程技術以降低成本，及晶圓代工及記憶體漲價效應，持續推升毛利率致本期淨利增加。

整體而言，該公司及其子公司營運獲利仍穩定成長，稅前淨利及每股盈餘仍呈逐期上升之態勢，其變化情形應屬合理。

(5)其他綜合損益

主要為退職後福利計畫之再衡量及國外營運機構財務報表換算產生之兌換差額，各期變化趨勢係受新台幣兌美金走勢影響，經評估尚無重大異常之情事。

(6)本期綜合損益總額

該公司及其子公司107~109年度及110 年截至第三季之綜合損益總額分別為6,902,701仟元、(2,754,403)仟元、3,719,627仟元及9,889,096仟元，金額變化主要隨營收成長，營業利益、稅前純益及本期淨利變動所致。整體而言，該公司及其子公司最近三年度及 110 年截至第三季之綜合損益總額變化情形尚無重大異常情事。

綜上所述，該公司及其子公司107~109年度及110 年截至第三季之損益變動狀況、與採樣同業相較尚無重大異常情事。

4.最近期及最近三個會計年度財務比率之變動分析及與同業之比較

單位：%；次；每股元

分析項目			年度 公司別	107年度	108年度	109年度	110年截至第三季
財務結構(%)	占資產比率	權益	力積電	44.22	40.71	42.09	48.99
			聯　電	56.65	55.98	62.45	註4
			世　界	78.19	69.01	67.68	註4
			華邦電	66.52	60.93	56.01	註4
			同　業	55.50	54.60	53.60	
		負債	力積電	55.78	59.29	57.91	51.01
			聯　電	43.35	44.02	37.55	註4
			世　界	21.81	30.99	32.32	註4
			華邦電	33.48	39.07	43.99	註4
			同　業	44.50	45.40	46.40	
	長期資金占不動產、廠房及設備		力積電	120.23	121.44	129.77	172.35
			聯　電	182.07	197.82	225.40	註4
			世　界	472.74	236.34	238.59	註4
			華邦電	151.61	153.20	163.65	註4
			同　業	209.21	187.62	198.41	
償債	流動比率		力積電	119.47	112.22	123.19	214.20
			聯　電	282.96	211.45	209.99	註4

分析項目			年度 公司別	107年度	108年度	109年度	110年截至第三季
能力(%)			世　界	358.91	190.60	194.35	註4
			華邦電	227.86	214.42	186.58	註4
			同　業	172.40	163.20	166.40	
	速動比率		力積電	79.32	67.79	76.71	172.90
			聯　電	223.98	172.94	178.20	註4
			世　界	309.13	160.81	165.96	註4
			華邦電	161.63	155.43	131.07	註4
			同　業	135.90	130.70	132.30	
經營能力	應收款項周轉率(次)(註2)		力積電	8.50	6.10	7.86	7.99
			聯　電	6.59	5.89	6.56	註4
			世　界	5.90	5.29	6.19	註4
			華邦電	7.55	7.53	7.43	註4
			同　業	4.90	5.00	5.40	
	應收款項收現天數(日)		力積電	43	60	47	46
			聯　電	56	62	56	註4
			世　界	62	69	59	註4
			華邦電	49	49	50	註4
			同　業	75	73	68	
	存貨周轉率(次)(註2)		力積電	5.39	5.01	4.88	4.60
			聯　電	7.04	6.36	6.23	註4
			世　界	6.05	5.50	7.08	註4
			華邦電	3.36	3.38	3.57	註4
			同　業	7.20	7.10	7.10	
	平均售貨天數(日)		力積電	68	73	75	80
			聯　電	52	58	59	註4
			世　界	61	67	52	註4
			華邦電	109	109	103	註4
			同　業	51	51	51	
	不動產、廠房及設備周轉率(次)		力積電	1.32	0.82	0.97	1.27
			聯　電	0.80	0.92	1.25	註4
			世　界	4.56	2.85	2.46	註4
			華邦電	1.06	0.89	1.02	註4
			同　業	3.10	2.70	2.70	
獲利能力	資產報酬率(%)		力積電	11.87	(3.15)	5.71	14.84
			聯　電	1.28	2.31	7.70	註4
			世　界	17.14	14.65	14.71	註4
			華邦電	8.55	1.65	1.52	註4
			同　業	8.30	6.40	8.50	
	權益報酬率(%)		力積電	23.37	(8.83)	12.07	30.90
			聯　電	1.26	2.96	12.27	註4
			世　界	21.52	19.88	21.34	註4
			華邦電	12.31	2.31	2.26	註4
			同　業	14.10	10.40	14.90	
	占實收資本比率(%)	營業利益	力積電	247.77	(6.76)	18.50	49.15
			聯　電	4.67	3.99	17.72	註4
			世　界	43.65	42.16	45.25	註4
			華邦電	19.92	3.15	4.09	註4
			同　業	註1	註1	註1	
		稅前純益	力積電	240.89	(8.42)	15.45	46.33
			聯　電	1.76	4.88	22.48	註4
			世　界	45.59	44.90	46.17	註4
			華邦電	21.09	4.40	4.55	註4
			同　業	註1	註1	註1	

分析項目		年度 公司別	107年度	108年度	109年度	110年截至第三季
	純益率(%)	力積電	13.85	(7.36)	8.33	21.57
		聯　電	1.75	4.14	15.37	註4
		世　界	21.32	20.72	19.03	註4
		華邦電	15.10	3.03	2.50	註4
		同　業	8.10	6.40	9.00	
	每股盈餘(元) (註3)	力積電	2.56	(0.94)	1.23	3.07
		聯　電	0.58	0.82	2.42	註4
		世　界	3.76	3.58	3.85	註4
		華邦電	1.87	0.32	0.33	註4
		同　業	註1	註1	註1	
現金流量	現金流量比率(%)	力積電	68.88	13.02	54.64	74.54
		聯　電	102.08	75.51	84.03	註4
		世　界	103.77	76.23	94.15	註4
		華邦電	82.17	60.38	43.64	註4
		同　業	20.00	25.70	33.70	
	淨現金流量適當比率(%) (註5)	力積電	84.14	54.31	75.83	95.77
		聯　電	79.96	90.89	107.04	註4
		世　界	83.75	71.36	69.99	註4
		華邦電	75.08	73.09	75.77	註4
		同　業	註1	註1	註1	
	現金再投資比率(%)	力積電	3.49	0.73	3.27	4.07
		聯　電	4.02	4.49	5.07	註4
		世　界	2.51	3.07	5.12	註4
		華邦電	5.20	3.31	3.67	註4
		同　業	5.50	6.70	9.10	
槓桿度	營運槓桿度 (註5)	力積電	4.26	(11.57)	5.97	2.99
		聯　電	13.99	16.34	4.43	註4
		世　界	2.33	2.41	2.73	註4
		華邦電	3.14	14.86	13.33	註4
		同　業	註1	註1	註1	
	財務槓桿度	力積電	1.06	0.80	1.13	1.04
		聯　電	1.91	2.67	1.10	註4
		世　界	1.00	1.01	1.01	註4
		華邦電	1.02	1.21	1.22	註4
		同　業	註1	註1	註1	

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證之合併財務報告及股東會年報，並經元大證券計算整理；同業資料取自財團法人金融聯合徵信中心所出版之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」財務比率。

註1：「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益占實收資本額比率、稅前純益占實收資本額比率、每股稅後盈餘、淨現金流量適當比率、營運槓桿度及財務槓桿度。

註2：應收帳款週轉率係以總額計算；存貨週轉率係以淨額計算。

註3：每股稅後盈餘係以基本每股盈餘作揭露。

註4：截至評估報告刊印日止，同業公司尚未出具經會計師核閱之財務報告。

註5：該公司及其子公司提供。

註6：財務分析之計算公式如下

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額

(2)權益占資產比率＝權益總額／資產總額

(3)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝(股東權益＋非流動負債)／不動產、廠房及設備淨額

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債

(2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付款項)／流動負債

3.經營能力

(1)應收款項週轉率＝銷貨淨額／平均應收款項總額

(2)應收款項收現天數＝365／應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨總額

(4)平均售貨天數＝365／存貨週轉率
(5)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額
4.獲利能力
(1)資產報酬率＝〔稅後純益＋利息費用(1－稅率)〕／平均資產總額
(2)權益報酬率＝稅後純益／平均權益總額
(3)營業利益占實收資本額比率＝營業利益／期末實收資本額
(4)稅前純益占實收資本額比率＝稅前純益／期末實收資本額
(5)純益率＝稅後純益／銷貨淨額
(6)每股盈餘＝(歸屬於母公司業主之損益－特別股股利)／加權平均已發行股數
5.現金流量
(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債
(2)淨現金流量適當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)
(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其它非流動資產＋營運資金)
6.槓桿度
(1)營運槓桿度＝(銷貨淨額－變動營業成本及費用)／營業利益
(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)

(1)財務結構

A.權益占資產比率及負債占資產比率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之權益占資產比率分別 44.22%、40.71%、42.09%及 48.99%；負債占資產比率分別為 55.78%、59.29%、57.91%及 51.01%，主係該公司基於營運策略考量，於 106 年購入竹南廠及生產設備以擴充產線，並向銀行申請聯貸案，使得負債比率整體偏高；108 年度負債占資產比率較 107 年度上升，主係竹南廠進行第二階段擴建專案，向銀行申請聯貸案所致；109 年度負債占資產比率下降，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營運資金增加所致；110 年第三季負債占資產比率較 109 年度下降，主係該公司於 110 年第一季辦理現金增資且收足股款，使得負債比率整體下降。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 107~109 年度負債占資產比率高於採樣公司及同業平均，主係因晶圓製造是一個高資本投入的行業，每年都會有資本支出計畫，在維護設備運作、既有產能去瓶頸化投資、或是建新廠，每家公司的產能建置狀況不同，所以每年度的不動產、廠房及設備投資金額也會有所差異，最近三年度及最近期該公司持續擴大營運，向銀行申請聯貸，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，故該等比率較差。惟隨該公司於 110 年第一季辦理第一次現金增資，於 110 年 6 月 11 日收足股款，並訂為現金增資基準日，110 年第三季財務報告負債比率隨之下降，尚無重大異常之情事。

B.長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 120.23%、121.44%、129.77%及 172.35%，108 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因擴建竹南廠增加長期銀行借款及租賃土地適用 IFRS 16 使用權資產之會計處理，租賃負債增加等使長期資金增加所致；

109 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、盈餘獲利使淨值提升所致；110 年第三季長期資金占不動產、廠房及設備比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利使淨值提升，且該公司為營運需求，向銀行增加借款及辦理現金增資所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，由於該公司積極擴建產能，不動產、廠房及設備金額自 108 年躍升為 474 億元後，持續維持在 470 多億或近 470 億元，再加上未來銅鑼 P5 的建廠計畫，未來會隨著驗收進度，持續增加不動產、廠房及設備金額。107~109 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率雖低於採樣公司及同業平均，惟該等比率大於 100%，顯示該公司長期資金尚足以支應營運所需之不動產、廠房及設備支出，且已逐年改善，110 年 6 月已完成總籌資金額 120 億元的增資案，再加上未來上市前現增可募集金額，將可大幅提高該比率，拉近與同業間的距離，尚無重大異常情事。

整體而言，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止之財務結構在營業規模成長及獲利連年挹注之下尚屬穩定，經評估應無重大異常之情事。

(2)償債能力

A.流動比率及速動比率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之流動比率分別為 119.47%、112.22%、123.19%及 214.20%，速動比率分別為 79.32%、67.79%、76.71 %及 172.90%，速動比率與流動比率變動趨勢相似，其 108 年度流動比率及速動比率較 107 年度低，主係該公司於 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入較 107 年度下降 28.08%，帳上現金及應收帳款下降，使得流動資產及速動資產減少；109 年度流動比率及速動比率較 108 年度高，係因該公司邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，再加上當年度的資本支出規模較低，使得營業活動淨現金流入已足以支應投資活動及籌資活動的淨現金流出，故使流動資產項目中現金、應收帳款及存貨等皆較 108 年度增加所致；110 年第三季流動比率及速動比率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營業收入增加，盈餘獲利使得營業活動淨現金流入，且該公司為營運需求，向銀行增加借款，另該公司於 110 年第一季辦理現金增資並於第二季

收足股款使得現金增加，綜上所述，帳上現金增加及應收帳款增加，使得流動資產及速動資產增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，107~109 年度該公司流動比率及速動比率低於採樣公司及同業平均，主係因由於該公司當初受讓力晶公司 12 吋晶圓製造相關營業資產與負債，連帶亦承接當初銀行團的聯貸契約，所以仍有部分歷史包袱需要再還，隨著業績狀況轉佳，公司已一步一步調整好財務體質，相關比率也越來越好，惟流動比率大於 100%。且隨該公司於 110 年第一季辦理第一次現金增資並於第二季收足股款，帳上現金增加，顯示該公司流動資產尚足以支應營運所需之流動負債，且該等比率 109 年度及 110 年第三季已隨營收成長逐步提升，償債能力尚屬穩健，經評估其流動比率及速動比率之變化應無重大異常情事。

綜上分析，該公司及其子公司最近三年度及申請年度截至最近期止之償債能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

(3)經營能力

A.應收款項週轉率及應收款項收現天數

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之應收款項週轉率分別為 8.50 次、6.10 次、7.86 次及 7.99 次；應收款項收現天數分別為 43 天、60 天、47 天及 46 天，108 年度應收帳款週轉率下降，主係 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降 28.08%，營業收入減少幅度高於平均應收款項總額減少幅度之故；109 年應收款項週轉率上升，係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致；110 年第三季應收款項週轉率略為上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長，較 109 年度增加所致。整體而言，該公司之往來客戶多為國內外知名大廠，營運規模、財務狀況及長期往來信用良好，帳款品質穩定，且最近三年度及最近期並無實際發生呆帳損失，並無重大異常情事。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 107 及 109 年度應收款項週轉率均優於採樣同業及同業平均，108 年度應收款項週轉率及收現天數均介於採樣同業之間，採樣同業間應收款項週轉情形差異主係因各公司之營運規模、收款政策及客戶組成不同所致，應無重大異常之情事。

B.存貨週轉率及平均售貨天數

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之存貨週轉率分別為 5.39 次、5.01 次、4.88 次及 4.60 次；平均售貨天數分別為 68 天、73 天、75 天及 80 天，該

公司係以接單式生產及計畫性生產兼具之生產方式安排生產排程及採購作業，以供應已承接訂單及長久穩定往來主要客戶之需求，存貨週轉率主要受到因訂單排程及客製化產品須提前備料，因而略有增減。108 年度存貨週轉率較 107 年度下降，主係 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降，使相對的銷貨成本減少所致；而 109 年度存貨週轉率下降，則主係隨著邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，109 年底為因應 110 年度訂單需求故增加原料備貨，109 年存貨淨額提升所致；110 年第三季存貨週轉率略為下降，係因半導體需求熱絡，為因應訂單需求故持續增加原料備貨，使平均存貨較 109 年度平均存貨增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 107~109 年度之存貨週轉率介於採樣公司及同業平均水準間，主係該公司記憶體產品之晶圓生產所需時間長於邏輯代工產品，故採樣同業相較之下低於邏輯代工同業如聯電與世界、高於記憶體同業華邦電，整體而言尚無重大異常情事。

C.不動產、廠房及設備週轉率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之不動產、廠房及設備週轉率分別為 1.32 次、0.82 次、0.97 次及 1.27 次，108 年度不動產、廠房及設備週轉率較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致當年度營業收入相較 107 年度下降，且擴建竹南廠增加資本支出，使平均不動產、廠房及設備淨額較 107 年增加所致；109 年度不動產、廠房及設備週轉率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，使銷貨收入增加所致，其營收成長幅度大於該年度之平均不動產、廠房及設備之幅度所致；110 年第三季不動產、廠房及設備週轉率上升，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司 107 年度不動產、廠房及設備週轉率介於採樣公司及同業平均，108 年度華邦電及同業平均水準之不動產、廠房及設備週轉率亦較 107 年度下滑，惟該公司不動產、廠房及設備週轉率皆低於採樣公司及同業平均水準，主係因 108 年受貿易紛爭干擾，全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振，導致記憶體價格下跌，該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，受到記憶體價格下跌影響較鉅，綜上所述造成 108 年度營收下滑，而使得不動產、廠房及設備週轉率低；109 年度不動產、廠房及設備週轉率低於採樣公司及同業平均水準，主係因該公司持續擴大營運，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，故造成固定資產淨額較高，惟在營運持續暢旺下，該公司於 109 年度不動產、廠房及設備週轉率逐漸提升。整體

而言，該公司產品別與華邦電相似，同時具有邏輯產品及記憶體產品，使得107~109 年度不動產、廠房及設備週轉率與華邦電相當，尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司之經營能力各項指標尚屬穩健，經評估尚無重大異常之情事。

(4)獲利能力

A.資產報酬率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之資產報酬率分別為 11.87%、(3.15)%、5.71%及 14.84%，108 年度資產報酬率較 107 年度低且為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少且公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故資產報酬率由負轉正；110 年第三季資產報酬率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司資產報酬率 107 及 109 年度皆介於採樣公司及同業平均水準，108 年度則低於採樣公司及同業平均水準，惟隨營運由虧轉盈且稅後純益逐年上升，顯示該公司資產報酬之運用效率尚稱穩健良好，顯示其資產報酬率尚無重大異常情事。

B.權益報酬率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之權益報酬率分別為 23.37%、(8.83)%、12.07%及 30.90%，108 年度股東權益報酬較 107 年度低且為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少且公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故權益報酬率由負轉正；110 年第三季權益報酬率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司權益報酬率 107 年度高於採樣

公司及同業平均，108 年度華邦電及同業平均水準之權益報酬率亦較 107 年度下滑，惟該公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；109 年度介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈權益報酬率逐漸上升，顯示該公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

C.營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之營業利益占實收資本額比率分別為 247.77%、(6.76)%、18.50%及 49.15%；稅前純益占實收資本額比率分別為 240.89%、(8.42)%、15.45%及 46.33%，107 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率較高，係因該公司於 108 年 5 月 1 日依企業併購法進行母子間組織重組，收購力晶科技股份有限公司(以下簡稱力晶科)12 吋晶圓廠相關資產負債，並發行新股予力晶科作為取得對價，此交易係屬於共同控制下的組織重組，應追溯視為自始合併並重編比較期間之合併報告，於 107 年度業經重編後的營業淨利及稅前純益係涵蓋受讓業務，然 107 年度實收資本額則未改變仍為未併購前金額，致使該比率有較大差異；108 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，使 108 年度處於虧損所致；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率皆由負轉正；110 年第三季營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司相較，該公司營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率，107 年度高於採樣公司，108 年度華邦電之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率亦較 107 年度下滑，惟該公司低於採樣公司，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；109 年度介於採樣公司，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

C.純益率及每股盈餘

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之純益率分別為 13.85%、(7.36)%、8.33%及 21.57%；每股稅後盈餘分別為 2.56、(0.94)、1.23 及 3.07，108 年度純益率及每股稅後盈餘較 107 年度低且為負數，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少，惟公司固定成本較高使得營業毛利顯著下降，致 108 年度處於虧損；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故純益率及每股稅後盈餘皆由負轉正；110 年第三季純益率及每股稅後盈餘增加，係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、盈餘獲利成長所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司純益率及每股稅後盈餘，108 年度華邦電之純益率及每股稅後盈餘亦較 107 年度下滑，惟該公司低於採樣公司及同業平均，主係因該公司記憶體產品占比與採樣公司產品別相較較高，其 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，綜上所述，使得 108 年度產生虧損所致；107 及 109 年度之純益率及每股稅後盈餘介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司之獲利能力良好且逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

(5)現金流量

A.現金流量比率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之現金流量比率分別為 68.88%、13.02%、54.64%及 74.54%，108 年度現金流量比率較 107 年度下降，主係該公司 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願致營業收入減少，使 108 年營業活動淨現金流入減少所致；109 年度現金流量比率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，故營業活動淨現金流量增加所致；110 年第三季現金流量比率上升，主係營業收入相較 109 年同期增加，且應收帳款收款狀況良好，使營業活動之淨現金流入上升。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司現金流量比率，108 年度低於採樣公司及同業平均，主係因該公司 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，營業收入減少使得營業活動淨現金流入減少所致；107 及 109 年度之現金流量比率介於採樣公司及同業平均，整體而言，隨營運由虧轉盈該等比率逐漸上升，顯示該公司之營運能力良好且

逐步健全，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

B.淨現金流量適當比率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之淨現金流量適當比率分別為 84.14%、54.31%、75.83%及 95.77%，108 年度淨現金流量適當比率較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致營業收入減少，使 108 年營業活動淨現金流入減少所致；109 年淨現金流量適當比率上升，主係因邏輯IC出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，營業活動淨現金流量增加所致；110 年第三季淨現金流量適當比率上升，主係因 110 年度半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長、營業活動淨現金流量增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司之淨現金流量適當比率 107 年度高於採樣公司及同業平均，108 年度低於採樣公司及同業平均，主係因該公司 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，使營運產生虧損所致，109 年度介於採樣公司及同業平均之間，整體而言，該公司淨現金流量適當比率逐步健全，經評估應無重大異常情事。

C.現金再投資比率

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之現金再投資比率分別為 3.49%、0.73%、3.27%及 4.07%，108 年度現金再投資比率較 107 年度下降，係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，致營業收入減少，使 108 年營業活動淨現金流入減少所致；109 年度現金再投資比率上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利，營業活動淨現金流量增加所致；110 年第三季現金再投資比率上升，主係因營收成長，營業活動現金流量增加所致。

與採樣公司及同業平均水準相較，該公司之現金再投資比率，107 年度介於採樣公司及同業平均，108 年度低於採樣公司及同業平均，主係因該公司 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，且加上該公司處於驅動 IC 產品新舊平台轉換過渡期，使營運產生虧損所致，109 年度低於採樣公司及同業平均，主係該公司持續擴大營運，投入大量資金興建竹南廠及生產設備以擴充產線，造成該比率低於採樣同業，然隨 109 年度營運由虧轉盈現金再投資比率逐漸上升，整體而言，該公司現金再投資比率逐步健全，經評估應無重大異常情事。

(6)槓桿度

A.營運槓桿度

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之營運槓桿度分別為 4.26、(11.57)、5.97 及 2.99，108 年度營運槓桿度較 107 年度下降，主係因 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，整體產能利用率下滑，使 108 年度處於營業虧損所致；109 年營運槓桿度上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長使營業收入增加所致。110 年第三季營運槓桿度下降，除獎金、員工酬勞及員工認股權等營業費用提升，固定支出增加外，另因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，晶圓代工產能供不應求，推升產品價格，使得營業利益上升，惟營業利益上升幅度大於固定支出，故造成營運槓桿度下降。

與採樣公司相較，該公司營運槓桿度，108 年度低於採樣公司，主係因該公司 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，營業收入減少導致營業虧損所致；107 年度、109 年度營運槓桿度介於採樣公司，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

B.財務槓桿度

該公司 107~109 年度及 110 年第三季之財務槓桿度分別為 1.06、0.80、1.13 及 1.04，108 年度財務槓桿度較 107 年度下降，主係該公司 108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願致營業收入減少，使 108 年營業虧損所致；109 年度財務槓桿度上升，主係因邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長使營業利益上升所致，110 年第三季較 109 年度稍微下降，係因晶圓代工產能供不應求，推升產品價格，使得營業利益上升，故造成財務槓桿度下降。

與採樣公司相較，該公司財務槓桿度，108 年度低於採樣公司，主係因該公司 108 年度記憶體產品之價格受全球經濟成長疲弱，消費市場需求不振影響而處於低檔，營業收入減少使得營業虧損所致；107 年度、109 年度之財務槓桿度介於採樣公司，整體而言經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

(二)發行人及其各子公司（包括母子公司間交易事項）最近期及最近三個會計年度背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易之情形及重大資產交易之情形，並評估其對公司財務狀況之影響

1.背書保證

該公司已訂定「背書保證作業程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為辦理背書保證作業之依據。經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及背書保證備查簿等，該公司及其子公司最近三年度及最近期並無對他人背書保證之情事。

2.重大承諾

經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及董事會議事錄等，該公司及其子公司之重大承諾事項及或有事項說明如下：

(1)該公司分別於 92 年 8 月、94 年 3 月、97 年 6 月、99 年 3 月、10 月、100 年 7 月及 102 年 7 月與 Micron Memory Japan,Inc.(原 Elpida Memory Inc.)簽屬若干動態隨機存取記憶體技術移轉與授權合約，該公司承諾自技術移轉完成後 5 年內支付一定金額之技術授權費及依約定產品之售價給付一定比例之權利金。惟雙方另於 100 年 5 月及 102 年 7 月簽屬合作協議，修訂權利金支付比例。

(2)該公司分別於 92 年 8 月及 94 年 3 月與某公司簽屬若干動態隨機存取記憶體技術之專利授權合約，該公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(3)該公司於 92 年 8 月與某公司等簽屬若干動態隨機存取記憶體之專利技術授權合約，該公司允諾自技術移轉完成後依約定產品之售價給付一定比例之權利金。

(4)該公司於 108 年 7 月與愛爾蘭遠東金士頓公司簽訂代工合約至 110 年 10 月 31 日止，該公司承諾以約定價格為其製造記憶體產品。

(5)該公司與數家供應商簽訂長期矽原料進貨合約，以確保矽原料穩定供貨，其中約定該公司須購買之相關最低數量及價格。

(6)該公司與客戶 Mitsubishi Electric Corporation 簽訂晶圓製造合約，其中針對晶圓製造的部分機器設備，係由 Mitsubishi Electric Corporation 提供，該公司及其子公司需負保管及使用之責。

(7)該公司與若干公司簽訂合約，於客戶提供保證金或其他擔保品後，該公司依合約約定期限提供特定產能予該客戶。

(8)該公司刻正興建新廠，與若干公司簽訂之工程建造合約總價 10,163,906 仟元，截至 110 年 9 月 30 日止尚未認列金額為 9,380,524 仟元。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及最近期之重大承諾事項皆為正常營業之所需，故對該公司及其子公司財務狀況尚無重大不利影響。

3.資金貸與他人

該公司已訂定「資金貸與他人作業程序」，業經董事會及股東會決議通過，作為辦理資金貸與作業之依據。經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及資金貸與他人備查簿等，該公司及其子公司最近三年度及最近期未有資金貸與他人之情形。

4.衍生性商品交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，業經董事會及股東會決議通過，

另該公司之子公司亦已訂定相關作業程序作為其衍生性商品交易之依據。經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會與股東會議事錄、公開資訊觀測站公告情形及衍生性金融商品備查簿等，該公司及其子公司最近三年度及最近期期末未到期之衍生性商品合約彙整如下：

單位：仟元

年度	交易類型	買入幣別及金額/賣出幣別及金額	交割日
107	賣出遠期外匯	NTD1,568,650/USD51,000	108.01.03~108.02.12
	賣出遠期外匯	JPY1,300,000/USD11,697	108.01.08~108.02.14
108	賣出遠期外匯	NTD152,300/ USD5,000	109.01.03
	賣出遠期外匯	JPY1,500,000/USD13,736	109.01.06~109.01.30
109	賣出遠期外匯	JPY2,350,000/USD22,553	110.01.07~110.02.08
110Q3	賣出遠期外匯	NTD2,112,176 /USD76,000	110.10.04~110.12.08
	賣出遠期外匯	JPY1,100,000/USD9,940	110.10.07~110.10.28

資料來源：該公司及其子公司提供

該公司及其子公司最近三年度及最近期衍生性商品主要係遠期外匯，其目的為規避該公司及其子公司外幣資產及負債因匯率波動產生之風險，相關交易業已依「取得或處分資產處理程序」執行，應無重大異常之情事。

5.重大資產交易

該公司及其子公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，業經董事會及股東會同意通過，另該公司之子公司亦已訂定相關作業程序作為其重大資產交易之依據。經參閱該公司及其子公司最近三年度及最近期公告明細、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、相關帳冊及董事會議事錄等資料，該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第三季重大資產交易情形列示如下：

單位：新臺幣仟元

標的物名稱	取得日期				取得總價款	實際付款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者，其原取得資料				取得目的	價格決定之參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會決議日					日期	對象	與公司之關係	價格		
工程設施	107/5/30	-	107/05/31	-	620,000	依雙方約定	洋基工程股份有限公司	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	107/9/25	-	107/10/01	-	682,676	依雙方約定	Applied Materials South East Asia Pte, Ltd	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/5/02	-	108/05/03	-	2,580,369	依雙方約定	香港商艾司摩爾貿易有限公司台灣分公司	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：董事長
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/05/08	-	108/05/09	-	1,031,927	依雙方約定	TOKYO ELECTR ON LIMITED	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/05/08	-	108/05/09	-	1,425,668	依雙方約定	Applied Materials South East Asia Pte, Ltd	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理

標的物名稱	取得日期				取得總價款	實際付款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者，其原取得資料				取得目的	價格決定之參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會決議日					日期	對象	與公司之關係	價格		
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/6/28	-	108/06/28	108/6/28	USD100,589	依合約議定，分期支付	Mitsubishi Electric Corporation	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：依雙方約定 (2)價格決定之參考依據：依雙方約定。 (3)決策單位：董事會
半導體產品生產製造設施及機器設備	108/10/21	-	108/10/22	-	1,263,951	依雙方約定	Integrated Silicon Solution, Inc.	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：依雙方約定 (2)價格決定之參考依據：依雙方約定。 (3)決策單位：總經理
收購母公司全部或主要部分之相關營業(含資產、負債及營業)	107/9/4	108/5/1	107/9/4	107/9/4	22,608,182	以每股發行價格新臺幣 10 元計算，該公司計發行新股 2,260,818,220 股	力晶科技股份有限公司	母公司	84.08.12~108.04.30	ASML Hong Kong Ltd. c/o ASML Netherlan ds B.V.、TOKYO ELECTR ON LIMITED、APPLIED MATERIALS Asia-Pacif ic, Ltd 及 其他…等	-	22,608,182	註 1	(1)交易之決定方式：董事會決議通過 (2)價格決定之參考依據：財團法人中華民國會計研究發展基金會(105)基秘字第 321 號「共同控制下子公司合併另一 100%持有之子公司之財務報表表達疑義」，共同控制下之合併個體性質為組織重組；故應按收購讓與基準日之原資產帳面價值 (3)決策單位：董事會 (4)取得外部專家意見：勤業眾信資產負債查核結果函、聯緯事務所合理意見書
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/3/9	-	109/3/9	109/3/9	1,000,000	依雙方約定	智豐料技股份有限公司	實質關係人	103.10～107.07	HIKE、東典、英福康、LAMRI、久福、恆鑫、EBARA、Edwards、Canon、AMAT、漢氏、崇越、PSK、	-	1,481,246	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：雙方議定 (2)價格決定之參考依據：雙方議定。 (3)決策單位：董事會 (4)取得外部專家意見：展茂資產管理顧問股份有限公司及詠宸資產評價有限公司 (5)配合生產製程計劃及資金規劃，故向智豐買回 consign 設備一批，供晶圓產品生產製造使用

標的物名稱	取得日期				取得總價款	實際付款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者，其原取得資料				取得目的	價格決定之參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會決議日					日期	對象	與公司之關係	價格		
										NISSIN-ION及其他等				
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/10/30	-	109/10/30	109/10/30	1,620,000	依雙方約定	聯發科技股份有限公司	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：雙方約定 (2)價格決定之參考依據：雙方約定。 (3)決策單位 ：董事會決議
興建廠房用之鋼構材料	109/12/18	-	109/12/19	-	1,820,000	依雙方約定	東鋼鋼結構股份有限公司	無	-	-	-	-	供建置廠房使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：董事長
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/3/12~109/12/24	-	109/12/25	-	1,120,610	依雙方約定	Applied Materials South East Asia Pte.Ltd.	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/3/26~110/2/8	-	110/2/8	-	1,014,544	依雙方約定	TOKYO ELECTRON LIMITED	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
租地委建	110/05/17	-	110/05/17	-	6,800,000	依雙方約定	互助營造股份有限公司	無	-	-	-	-	興建供晶圓產品生產製造用廠房	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：董事長
半導體產品生產製造設施及機器設備	110/1/13~110/8/5	-	110/08/05	-	1,149,673	依雙方約定	Applied Materials South East Asia Pte.Ltd.	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
興建廠房用之消防系統工程	110/1/13~110/8/5	-	110/08/19	-	1,262,665	依雙方約定	正德防火工業股份有限公司	無	-	-	-	-	供建置廠房使用	(1)交易之決定方式：比價及議價

標的物名稱	取得日期				取得總價款	實際付款情形	交易對象	與公司之關係	交易對象為關係人者，其原取得資料				取得目的	價格決定之參考依據
	訂約日	過戶日	公告日	董事會決議日					日期	對象	與公司之關係	價格		
														(2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	109/12/22~110/9/3	-	110/09/03	-	1,258,935	依雙方約定	KLA CORPORATION	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
興建廠房用之工程設施	110/8/24~110/9/7	-	110/09/07	-	1,036,000	依雙方約定	互助營造股份有限公司	無	-	-	-	-	供建置廠房使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理
半導體產品生產製造設施及機器設備	110/09/24	-	110/09/24	110/09/24	USD 40,000	依雙方約定	NXP Semiconductors Netherlands B.V.	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：雙方約定 (2)價格決定之參考依據：雙方約定。 (3)決策單位 ：董事會決議
半導體產品生產製造設施及機器設備	110/9/3~110/9/27	-	110/09/27	-	1,022,187	依雙方約定	KLA CORPORATION	無	-	-	-	-	供晶圓產品生產製造使用	(1)交易之決定方式：比價及議價 (2)價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。 (3)決策單位：總經理

資料來源：該公司及其子公司提供

註 1：組織重組發行新股收購母公司力晶科技股份有限公司全部或主要部分之相關營業(含資產、負債及營業) (依企業併購法第 28 條)；故應按收購讓與基準日之原資產帳面價值入帳。

該公司及其子公司考量滿足公司營運規劃所需，陸續購買半導體產品生產製造設施、機器設備及興建廠房用之鋼構材料等，上述重大資產交易案為金額達新臺幣三億元或實收資本額百分之二十以上，交易過程均係依「取得或處分資產處理程序」規定辦理，交易係由多筆採購彙總，已依內部決策過程經核決層級核決通過，或已按照「取得或處分資產處理程序」提報董事會通過，其交易目的與決策過程尚無重大異常之情事，對該公司及其子公司之財務狀況尚不致產生重大不利之影響。

綜上所述，該公司及其子公司最近三年度及最近期並無背書保證、資金貸與他人之情事，而衍生性商品、重大承諾及重大資產交易之情形，皆為正常營運發展所需，尚無重大異常情事，故對該公司及其子公司財務狀況尚無重大影響。

(三)發行人最近期及最近三個會計年度資金募集及每股盈餘變化情形

單位：新臺幣仟元

年度 名稱	107 年度	108 年度	109 年度	110 年截至第三季
期初股本	3,063,642	3,586,674	31,051,965	31,051,965
股票股利	523,032	857,109	—	—
現金增資	—	4,000,000	—	3,000,000
組織重組	—	22,608,182	—	—
註銷庫藏股	—	—	—	(3)
期末股本	3,586,674	31,051,965	31,051,965	34,051,962
營業收入淨額	49,913,779	35,897,121	45,684,615	45,865,144
稅後淨利(損)	6,914,744	(2,643,184)	3,806,477	9,891,995
基本每股盈餘(虧損)(元)	2.56	(0.94)	1.23	3.07

資料來源：該公司 107~109 年度及 110 年第三季該公司經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

該公司及其子公司 107 年度期初普通股股本為 3,063,642 仟元至 110 年第三季底普通股股本為 34,051,962 仟元，增加 30,988,320 仟元，主要係股票股利、現金增資及組織重組所致。股票股利主係該公司營運考量，以股票形式發放予股東；組織重組主係該公司於 108 年度受讓該公司之母公司營業讓與，該公司以發放新股作為取得之對價；現金增資所募資金之運用情形及效益請詳本評估報告「肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。

該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第三季營業收入淨額分別為 49,913,779 仟元、35,897,121 仟元、45,684,615 仟元及 45,865,144 仟元；稅後淨利(損)分別為 6,914,744 仟元、(2,643,184)仟元、3,806,477 仟元及 9,891,995 仟元；稅後基本每股盈餘(虧損)分別為 2.56 元、(0.94)元、1.23 元及 3.07 元，其中該公司及其子公司 107~109 年度及 110 年第三季營業收入變動，108 年度邏輯產品的需求下降及記憶體價格處於低檔，客戶減少拉貨意願，再加上驅動 IC 產品新舊技術平台轉換等因素，使得整體產能利用率下滑，致營業收入減少；109 年度邏輯 IC 出貨暢旺且記憶體報價自谷底回溫，營收成長、營運獲利；110 年第三季係因半導體需求熱絡，隨著 5G、車用電子及物聯網等晶片需求快速興起，與新冠肺炎疫情帶動之居家工作、遠距教學等宅經濟風潮，使筆電、平板及手機等終端裝置銷售遞增，致面板用之驅動 IC、電源管理 IC 及 CIS 等晶片需求持續暢旺，並帶動記憶體市場呈現復甦，造成成熟製程晶片需求大幅增加，晶圓代工產能供不應求，該公司營收成長，而稅後淨利(損)及每股盈餘(虧損)主係受營業淨利及營業外收支影響而有所變化。該公司雖於 108 年度及 110 年第一季共計辦理現金增資 700 仟股，然對股本之影響有限故並未對其每股盈餘造成重大影響，其 107~109 年度及 110 年第三季每股盈餘之變動主係受到營業收入波動

影響所致，整體而言，該公司及其子公司每股盈餘之變化應無因對外公開募集資金而使股本過度膨脹、獲利稀釋而損及股東權益之情事。

(四)本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益。前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

1.本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益。

該公司本次募資計畫係用於擴建廠房，故不適用本項評估。

2.前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形。

該公司本次募資計畫係用於擴建廠房，故不適用本項評估。

(五)發行人其他特殊財務狀況

經參閱該公司最近三個會計年度及申請年度最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並無發現該公司有其他特殊財務狀況之情事。

肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫

(一)110 年度現金增資案

1.計畫內容

(1)目的事業主管機關核准日期及文號：110 年 03 月 19 日金管證發字第 1100335468 號核准。

(2)計畫所需資金總額：新臺幣 12,000,984 仟元。

(3)資金來源

A.現金增資發行普通股 300,000 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股溢價發行價格為新台幣 40 元，預計募集總金額為新台幣 12,000,000 仟元。

B.自有資金：984 仟元。

(4)計畫項目及資金運用情形

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預訂完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度					
			110 年度		111 年度			
			第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季
機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施	111 年第四季	12,000,984	3,460,634	620,685	3,334,029	418,339	2,410,868	1,756,429

(5)預計可能產生效益

單位：新臺幣仟元

年度	項目名稱	生產量	銷售量	銷售值	毛利	營業利益
112	晶圓代工	245	245	6,795,074	2,304,858	1,761,252
113	晶圓代工	245	245	6,795,074	2,304,858	1,761,252
114	晶圓代工	245	245	6,795,074	2,304,858	1,761,252
115	晶圓代工	245	245	6,795,074	2,304,858	1,761,252

資料來公：該公司提供。

2.計畫執形情形

單位：新臺幣仟元

計畫項目	執行狀況		110 年度			111 年度				進度超前或落後情形、原因及改進計畫
			第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	
機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施	支用金額	預定	0	3,460,634	620,685	3,334,029	418,339	2,410,868	1,756,429	該公司於募集資金到位後，依設備付款條件支付
		實際	107,854	2,311,773	-	-	-	-	-	
	執行進度	預定	0.00%	28.84%	5.17%	27.78%	3.49%	20.09%	14.64%	
		實際	0.89%	19.26%	-	-	-	-	-	

3.計畫落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫

該公司為因應未來營運發展規畫，本次募集資金主係用於購置機器設備、廠務設備、研發設備及其附屬設施以擴充產能、提升生產製程及增進研發能力。本次計畫落後之原因主係因該公司係依設備付款條件支付款項，因相關設備仍處採購、安裝階段，部份設備尚未選定供應商，且設備驗收時程較冗長，故尚未具體產生執行效益，經評估對股東權益並無重大影響。

二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益

該公司及其子公司截至評估報告日止並無辦理發行公司債及私募有價證券，前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股，並無重大變更之情事，故不適用本項評估。

三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響

(一)108 年度公開發行前辦理第一次發行新股作為受讓力晶科技相關 12 吋晶圓廠及相關營業、淨資產案之對價

1.計畫內容

(1)目的事業主管機關核准日期及文號：108 年 05 月 13 日竹商字第 1080012910 號函核准。

(2)計畫所需資金總額：新臺幣 22,608,182 仟元。

(3)資金來源：增資發行新股 2,260,818 仟股，每股面額 10 元，總計增加實收股本 22,608,182 仟元，以每股普通股面額 10 元原價發行換取力晶科技所讓與營業與淨資產之帳面價值。

(4)計畫項目及資金運用情形：力晶科技為有效整合集團資源，進行組織重組提高整體競爭力，故將全部或主要部分之相關營業及淨資產受讓予該公司，由該公司自收購讓與基準日起承受力晶科技之相關營業及淨資產，並由該公司發行新股予力晶科技作為對價。

2.計畫執形情形

該公司業於 108 年 05 月 01 日收購讓與基準日完成受讓並發行新股相關事項，並於 108 年 05 月 13 日完成辦理變更登記。

3.執行效益分析

該公司於本次受讓發行新股之執行效益顯現於 107 年度及 108 年上半年度之兩期間財務數字差異結果，請詳下表。

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度		107 年度	108 年上半年度
基本財務資料	流動資產	3,601,769	19,027,326
	不動產、廠房及設備	7,544,622	46,272,607
	總資產	11,918,488	69,698,850
	流動負債	3,952,307	17,101,445
	負債總額	7,021,049	42,928,243
	營業收入	7,637,449	16,757,678
	利息支出	729	221,306
	每股盈餘(元)	2.22	(0.63)
財務結構	負債占資產比率	58.91%	61.59%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	105.59%	113.67%

註：各期為經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告；其中 107 年度係為未追溯重編之財務資料。

該公司於 108 年 05 月完成受讓力晶科技相關營業及淨資產，經由本次組織重組，有效整合集團資源進而提升生產動能，以降低未來營運受全球總體經濟因素變遷之不確定性。在營運成果方面，該公司 108 年上半年度營業收入已達 16,757,678 仟元，每股盈餘方面 108 年上半年度為(0.63)元，較 107 年度為低，主係因受讓力晶科技之相關營業及淨資產，方於 108 年 05 月才完成所致，經由此次受讓並進行增資發行新股使該公司得以專心致力於代工事業發展，進一步提升營運績效，故該公司本次受讓力晶科技淨資產發行新股之計畫執行效益已顯現。

(二)108 年度公開發行前辦理第二次現金增資案

1.計畫內容

(1)目的事業主管機關核准日期及文號：108 年 10 月 01 日竹商字第 1080028229 號函核准。

(2)本次計畫所需資金總額：新臺幣 4,040,000 仟元。

(3)資金來源：於 108 年 09 月 06 日辦理現金增資發行普通股 400,000 仟股，每股發行價格為新臺幣 10.1 元，募集總金額為新臺幣 4,040,000 仟元。

(4)計畫項目及資金運用情形

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所須資金實際總額	實際或預定資金運用情形	
			108 年第四季	109 年第一季
充實營運資金	109 年第一季	4,040,000	2,020,000	2,020,000

2.計畫執形情形

單位：新臺幣仟元

計畫項目	執行狀況		108 年第四季	109 年第一季	進度超前或落後情形、原因及改進計畫
充實營運資金	支用金額	預定	2,020,000	2,020,000	-
		實際	2,020,000	2,020,000	
	執行進度	預定	50%	100%	
		實際	50%	100%	

3.執行效益分析

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度		108 年第二季(增資前)	108 年第二季(增資後)
基本財務資料	流動資產	19,027,326	23,067,326
	流動負債	17,101,445	17,101,445
	資產總額	69,698,850	73,738,850
	負債總額	42,928,243	42,928,243
	利息支出	221,306	221,306
	營業收入	16,757,678	16,757,678
	每股盈餘	(0.63)	(0.55)
財務結構	負債占資產比率	61.59%	58.22%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	113.67%	122.40%
償債能力	流動比率	111.26%	134.89%
	速動比率	65.90%	89.53%

資料來源：108 年第二季為擬制整併後追溯重編之經會計師核閱簽證合併財務報表。
註：增資後之相關數據係依 108 年第二季募集資金推估。

本次計畫用於充實營運資金，業於 108 年第三季募集完成，預計在資金之挹注下，短期而言營業收入雖未增加，惟預計中長期將對該公司之營運規模擴展將有正面之助益。此外隨著 108 年第三季完成增資後，負債占資產比率亦隨著資產增加而降低至 58.22%，利息支出並無影響；在財務狀況方面，該公司流動比率及速動比率皆較 108 年第二季增資前的比率提升，提高自有資本比率，顯示該公司增資後較增資前已逐步健全財務結構，故本次增資效益應有合理顯現。

四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務周轉困難情事

經參閱該公司及其子公司最近三個會計年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會會議記錄，該公司及其子公司並無發行公司債或舉借長期債務未如期還本付息之情事，且最近三個會計年度亦無財務週轉困難之情事。

五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開

該公司及其子公司並無辦理私募有價證券之情事，故不適用本項評估。

伍、就本次募集與發行有價證券之適法性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項性質依附表九之一中所列事項詳與評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行

該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，辦理現金增資發行新股以供證券承銷商辦理上市前公開承銷之用，非依同準則第六條第二項第一款或第三款募集與發行有價證券，故不適用同準則第十三條第一項第二款所列情事之評估。

二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事

(一)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事之承銷商審查意見如下：

審查情事	有無左列情事		評估依據
	有	無	
1.簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告者。		✓	經參閱該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，簽證會計師並無出具無法表示意見或否定意見之查核報告，故無左列之情事。
2.簽證會計師出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者。		✓	經查閱該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，簽證會計師並無出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者，故無左列之情事。
3.發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，顯示有違反法令或公司章程，致影響有價證券之募集與發行者。		不適用	該公司本次辦理現金增資發行新股係供初次上市前公開承銷之案件，依法令規定無需檢附發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，故不適用。
4.律師出具之法律意見書，表示有違反法令，致影響有價證券之募集與發行者。		✓	經參閱律師對本次現金增資發行新股出具之法律意見書，該公司並無違反法令，致影響有價證券募集與發行之情事。
5.證券承銷商出具之評估報告，未明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性者。		✓	本承銷商出具之評估報告，已明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性。(詳評估報告「陸」之說明)。
6.經金管會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報(請)案		✓	經檢視該公司107~109年度及110年度截至評估報告出具日前止之董事會及股東會議事錄、該公司與金管會之往來文件，並詢問該公司相

審　查　情　事	有無左列情事		評　估　依　據
	有	無	
件，發行人自接獲金管會通知即日起三個月內辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項規定之案件者。但本次辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，不在此限。			關人員，並無左列情事。
7.申報現金增資或發行公司債案件，直接或間接赴大陸地區投資金額違反經濟部投資審議委員會規定者。但其資金用途係用於國內購置不動產、廠房及設備並承諾不再增加對大陸地區投資，不在此限。		✓	經查閱該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會議事錄，該公司本次募集資金之運用計畫並無用於直接或間接赴大陸地區投資之情事，故無左列情事。
8.上市、上櫃公司或興櫃股票公司未依證券交易法第十四條之六第一項規定設置薪資報酬委員會或未依相關法令規定辦理，情節重大者。		✓	經參閱該公司相關董事會議事錄，該公司已依法設置薪資報酬委員會，並依相關法令規定訂定其組織章程及委任薪資報酬委員，截至評估報告出具日止，並無左列情事。
9.未依公司法第一百七十七條之一第一項但書規定將電子方式列為表決權行使管道之一者。		✓	該公司已於公司章程明訂將電子方式列為表決權行使管道之一，故無左列情事。
10.違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大者。		✓	經查閱該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會及股東會之議事錄、與金管會之往來函文，及取得該公司出具之聲明書，截至評估報告出具日止，尚未發現該公司有重大違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時承諾事項之情事。
11.經金管會發現有違反法令，情節重大者。		✓	經查閱律師所出具之法律意見書、該公司董事會議事錄與主管機關之往來函文，並取具公司聲明書，該公司截至評估報告出具日止，並無左列情事。

(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列情事之承銷商審查意見如下：

審　查　情　事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
1.申報年度及前二年度公司董事變動達二分之一，且其股東取得股份有違反本法第四十三條之一者。但於申報日前已完成補正者，不在此限。		✓		經參閱該公司107～109年度及110年截至評估報告出具日止之董事會、股東會議事錄及變更登記事項表。該公司為符合申請興櫃掛牌之規定，於109年11月24日召開股東臨時會增補選四席董事(包含三席獨董)，以及為強化公司治理，於110年4月9日接獲同一任期中二席法人董事將於同年6月8日辭任之辭任書，且於110年7月2日股東會補選二席獨立董事，故該公司董事變動達1/2以上。惟該公司股東取得該公司股份並無違反證交法第四十三條之一規定。故無左列情事。
2.上市或上櫃公司有證券交易法第一百五十六條各款情事之一者。但依證券交易法第一百三十九條第二項規定限制其上市買賣者，不在此限。				
(1)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。		✓		經查閱律師所出具之法律意見書、該公司107～109年度及110年截至評估報告出具日止與主管機關之往來函文、經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會議事錄，並取具該公司聲明書，並未發現該公司有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產之情事發生。
(2)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更。		✓		經參酌律師填報之法律事項檢查表、核閱該公司107～109年度及110年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、目前存續之重要契約、經會計師查核簽證之財務報告及無退票紀錄查覆單，截至評估報告出具日止，該公司並無遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計劃之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。
(3)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足		✓		經參酌律師填報之法律事項檢查表、核閱該公司107～109年度及110年截至評估報告出

審　查　情　事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
以影響其證券價格。				具日止之董事會及股東會議事錄、主管機關往來函文、經會計師查核簽證之財務報告，並取得該公司出具之聲明書，截至評估報告出具日止，該公司尚無虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。
(4)該有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌。			✓	該公司目前為興櫃市場掛牌之公司，尚未於上市或上櫃市場掛牌交易，故不適用左列之評估。
(5)發行該有價證券之公司發生重大公害或食品藥物安全事件。		✓		經參閱該公司107~109年度及110年截至目前之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並參酌律師出具之法律意見書及法律事項檢查表，該公司並無發生重大公害或食品藥物安全事件，而有影響市場秩序或損害公益之情事。
(6)其他重大情事。		✓		經參閱該公司107~109年度及110年截至目前之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司尚無其他重大情事，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。
3.本次募集與發行有價證券計畫不具可行性、必要性及合理性者。		✓		經本承銷商評估該公司本次募集與發行有價證券計畫確有其可行性、必要性及合理性。(詳評估報告「陸」之說明)
4.前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行有下列情事之一，迄未改善者：				
(1)無正當理由執行進度嚴重落後，且尚未完成。		✓		該公司並無私募有價證券之情事，且該公司前各次募集資金計畫均依計畫項目執行完畢，並未有左列之情事。
(2)無正當理由計畫經重大變更。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。			✓	該公司並無私募有價證券之情事，且該公司前各次募集資金計畫均依計畫項目執行完畢，並無計畫經重大變更之情事。
(3)募集與發行有價證券計畫經重大變更，尚未提報股東會通過。			✓	經查閱該公司之董事會與股東會議事錄及公開資訊觀測站之公告資訊，該公司截至評估報告出具日止，前各次募集與發行有價證券並無變更計畫之情事，故無左列之適用。

審　查　情　事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(4)最近一年內未確實依第九條第一項第四款至第九款及發行人募集與發行海外有價證券處理準則第十一條規定辦理。		✓		經參閱該公司與主管機關往來函文，查詢公開資訊觀測站相關公告資料，該公司最近一年內募集有價證券並無未依「發行人募集與發行有價證券處裡準則」第九條第一項第四款至第九款辦理之情事，且該公司並無募集與發行海外有價證券之情事。
(5)未確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開，情節重大。			✓	經查閱該公司107~109年度及110年截至評估報告出具日止之董事會與股東會議事錄、查詢公開資訊觀測站相關資料，該公司未曾辦理私募有價證券之情事，故不適用左列事項之評估。
(6)未能產生合理效益且無正當理由。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。		✓		除該公司110年度現金增資案其進度尚未達產生預期效益之年度外，該公司前各次募集與發行有價證券計畫並無左列之情事。
5.本次募集與發行有價證券計畫之重要內容(如發行辦法、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等)未經列成議案，依公司法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。		✓		該公司本次計畫重要內容已列成議案，於110年10月19日董事會討論並決議通過，故無左列之情事。
6.非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。		✓		經查閱該公司107～109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及相關明細帳，截至案件評估日止，該公司尚無左列情事。
7.有重大非常規交易，迄未改善者。		✓		經查閱該公司107～109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會及股東會會議記錄，截至案件評估日止，該公司尚無左列情事。
8.持有具流動性質之金融資產投資、閒置性資產或投資性不動產而未有處分或積極開發計畫，達最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告歸屬於母公司業主之權益之百分之四十或本次申報現金增資或發行公司債募集總金額之百分之六十，而辦理現金增資或發行公司債者。但所		✓		該公司未有大量持有流動資產項下之金融資產、閒置資產或投資性不動產而未有處分或積極開發計畫之情事。

審　查　情　事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
募得資金用途係用於購買不動產、廠房及設備且有具體募資計畫佐證其募集資金之必要性，不在此限。				
9.本次現金增資或發行公司債計畫之用途為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者。		✓		經查閱該公司董事會議事錄，該公司本次現金增資發行新股計畫之用途並非為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者，故無左列之情事。
10.不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，情節重大者。		✓		經查閱該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並無左列之情事。
11.違反「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定情事者。		✓		經查閱該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會及股東會會議記錄及收發文記錄，該公司並無左列情事，未來若發布財務預測資訊將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條第二項規定，自申報日起至申報生效前，除依法令發布之資訊外，不得對特定人或不特定人說明或發布財務業務之預測性資訊。
12.內部控制制度之設計或執行有重大缺失者。		✓		經參閱該公司內控聲明書、稽核報告、稽核工作底稿及其簽證會計師出具之內部控制建議書內容，該公司內部控制制度應尚屬有效執行，並未發現有重大缺失之情事。
13.申報日前一個月，其股價變化異常者。		✓		經查詢櫃檯買賣中心所公告之興櫃股票達通知標準資訊，該公司申報日前一個月間並無股價變化異常情事。
14.公司全體董事或監察人持股有下列情形之一者：				
(1)違反本法第二十六條規定，經金管會通知補足持股尚未補足。		✓		本年度截至案件申報時止，該公司股份總額為3,405,196,242股，而其全體董事持股總數為969,260,136股，占該公司發行股數之28.46%，另該公司已設置審計委員會取代監察人，經評估已符合「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定，故無左列情事。

審　查　情　事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(2)加計本次申報發行股份後，未符本法第二十六條規定。但經全體董事或監察人承諾於募集完成時，補足持股，不在此限。		✓		該公司截至案件申報時止，全體董事持股數為969,260,136股，全體董事持股數占已發行股份總數加計本次現金增資後之實收資本股數3,535,196,242股之比例為27.42%，故應無違反證交法第二十六條之疑虞。
(3)申報年度及前一年度公司全體董事或監察人未依承諾補足持股。		✓		經查閱該公司109年度及110年度截至評估報告日止與金管會往來文件，並未發現該公司有左列情事。
15.發行人或其現任董事長、總經理或實質負責人於最近三年內，因違反本法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法等工商管理法律，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		✓		經核閱本次募集與發行所出具之法律意見書、該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會與股東會議事錄，並取具該公司及現任董事長、總經理相關聲明書，並未發現有左列之情事。
16.因違反證券交易法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，迄未依法履行者。		✓		經參閱本次募集與發行所出具之法律意見書、該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會與股東會議事錄，並未發現該公司並有左列之情事。
17.為他人借款提供擔保，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條規定，情節重大，迄未改善者。		✓		經參閱該公司107~109年度及110年第三季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及董事會議事錄，該公司截至評估日止，並無違反左列之情事。
18.合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，而有下列情形之一者： (1)違反金管會公開發行公司取得或處分資產處理準則第二章第五節之規定，情節重大。 (2)受讓或併購之股份非為他公司新發行之股份、所持有非流動之股權投資或他公司股東持有之已發行股份。			✓	該公司本次辦理上市前現金增資發行新股計畫，非屬合併發行新股、受讓他公司股份發行新股或依法律規定進行收購或分割發行新股，故不適用左列之規定。

審　查　情　事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(3)受讓之股份或收購之營業或財產有設質或限制買賣等權利受損或受限制之情事。 (4)違反公司法第一百六十七條第三項及第四項之規定。 (5)被合併公司最近一年度之財務報告非經會計師出具非無保留意見之查核報告。但經出具保留意見之查核報告，其資產負債表經出具無保留意見，不在此限。				
19.有第十三條第一項第二款第六目規定之情事，且有下列情形之一： (1)申報現金發行新股，公司董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東未承諾將一定成數股份送交證券集中保管事業保管。 (2)申報發行轉換公司債或附認股權公司債。			✓	該公司本次係辦理現金增資發行新股以供辦理上市前公開承銷，非依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第一項第一款或第三款募集與發行有價證券，亦無第十三條第一項第二款第六目之情事，故本項不適用。
20.證券承銷商於發行人申報時最近一年內經金管會、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上，且自被處記缺點累計達十點之日起未逾三個月。但興櫃股票公司辦理現金發行新股為初次上市、上櫃公開銷售者，不在此限。			✓	本證券承銷商於該公司申報時最近一年內並未經金融監督管理委員、證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及中華民國證券商業同業公會處記缺點累計達十點以上之情事。且本案係屬興櫃股票公司辦理現金發行新股為初次上市公開銷售者，故不適用本項評估。
21.其他金管會為保護公益認為有必要者。		✓		經查閱該公司與金融監督管理委員會之往來函文，並無左列情事。

經上述評估，該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件並無違反「發行人募集與

發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事。

三、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定

該公司本次募集與發行有價證券係屬現金增資發行普通股，故針對「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第壹章總則第一條至第四條及第貳章現金增資普通股第五條至第九條之規定，逐條評估如下：

自律規則條款	說明
第一條：為推動有價證券之發行，並保障投資，除其他法令另有規定外，本公會承銷商會員輔導發行公司或外國發行人辦理募集與發行有價證券事宜時應遵守本自律規則。	本承銷商輔導該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件謹遵守本自律規則辦理。
第二條：承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券時，主辦承銷商與發行公司或外國發行人間不得有下列情事： 一、任何一方與其母公司、母公司之全部子公司，合計持有對方股份總額百分之十以上者。 二、任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。 三、任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。 四、任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。 五、任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。 六、任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。但證券承銷商為金融機構或金融控股公司之證券子公司時，如其母公司、母公司之全部子公司總計持有發行公司股份未逾發行公司已發行股份總額百分之十，且擔任發行公司董事或監察人席次分別未逾三分之一者，不在此限。 七、雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。 八、其他法令規定或事實證明任何一方直接或	經查核元大證券(股)公司與該公司之董事、大股東、經理人及關係人間之關係，雙方並無左列情事，且雙方亦已出具聲明書，聲明並無左列各項限制條款之一者，故元大證券(股)公司得為該公司募集與發行有價證券之主辦承銷商。

自律規則條款	說明
間接控制他方之人事、財務或業務經營者，致有失其獨立性之情事者。 發行公司或外國發行人發行普通公司債及未涉及股權之金融債券，如銷售對象僅限於證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人，其主辦承銷商得不受前項規定之限制，發行公司或外國發行人如具證券承銷商之資格者，亦得擔任主辦承銷商。 本條所稱母公司及子公司，應依證券商財務報告編製準則規定認定之。	
第二條之一：承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券應取得填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司或外國發行人、會計師及證券商具有下列關係之聲明書： 一、財務會計準則公報第六號規定之關係人關係。 二、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。 依發行人募集與發行海外有價證券處理準則或外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定出具海外存託憑證、海外股票或海外公司債發行辦法與行政院金融監督管理委員會同意生效內容無重大差異意見書中文本之律師，亦應符合前項之規定。	經取具傑宇法律事務所陳維鈞律師所出具之聲明書，本次出具法律意見書之日，傑宇法律事務所陳維鈞律師於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且與該公司、會計師及本承銷商並無左列關係之情事。
第三條：承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券，應於向本公會申報承銷契約副本時，檢送有關承銷商與發行公司或外國發行人於向金管會或其委託之機構申報案件至繳款截止日止，其相關宣傳或資訊揭露應以公開說明書所載內容為限之聲明書；承銷商並應複核發行公司或外國發行人有無違反前開規定。前項聲明書之聲明事項，應增列有關不得對特定人或不特定人說明或發布除依金管會「公開發行公司公開財務預測資訊處理	本承銷商於向證券商同業公會申報承銷契約副本時，將依左列規定辦理。

自律規則條款	說明
準則」辦理公告之財務預測資訊內容以外之其他財務業務預測性資訊。 經主管機關依證券交易法第二十二條第一項核定免向金管會申報生效者， 第一項聲明書之聲明期間以向金管會申請案件至繳款截止日止。	
第四條：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券(員工認股權憑證除外)，加計其前各次(含其所私募者)上述有價證券流通在外餘額依各別轉換(認購)價格設算轉換(認購)後所增加之股數，不得逾已發行股數之百分之五十。 發行公司或外國發行人以已發行之股份做為轉換(認購)之用者，其做為轉換(認購)用之已發行股份不列入前項增加股數之計算。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之一：承銷商輔導發行公司申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，以新發行之股份履行轉換義務或履約者，承銷商應加強輔導發行公司採取股票無實體發行之制度，惟自九十五年七月一日起，上市、上櫃及興櫃股票公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。 承銷商輔導外國發行人募集與發行有價證券之交付，除外國發行人註冊地國另有規定外，應以帳簿劃撥方式為之。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之二：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司之發行與轉換(認購)辦法中應訂明「自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換(認購)」規定；另應注意避免現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起暫停轉換(認購)期間與前各次具轉換(認股、交換)	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。

自律規則條款	說明
有價證券到期日前之停止轉換(認股、交換)期間接續，及已發行流通在外之轉換公司債其轉換股份時先交付股票再辦理變更登記者，如遇普通股除息、除權或現金增資認股時，應符合證交所「營業細則」及櫃檯中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第十條有關二階段公告規定。 前項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換（認購）期間。	
第四條之三：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券，自發行日後屆滿一定期間起，除依法暫停過戶期間外，持有人得依發行人所定之發行及轉換(認股、交換)辦法請求轉換(認股、交換)；但發行公司或外國發行人為未上市（櫃）、未登錄興櫃之公開發行公司者，轉換（認股、交換）期間自發行日後屆滿一定期間至到期日前十日止為限。 前項所稱一定期間不得少於三個月，並應由發行人或外國發行人於轉換(認購、交換)辦法中訂定之。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之五：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換(交換、認購)性質之各種有價證券，應就發行年期、發行價格、贖回時點、轉換溢價率、收益率、賣回時點、擔保狀況、分券狀況等因素綜合評估其發行條件訂定之合理性。 對於發行條件顯不相當者，承銷商應輔導發行公司或外國發行人於重新合理訂定發行條件後，再行送件。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之六：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行海外有價證券，其按發行價格計算之發行金額，應高於二仟萬美元。但發行公司確有外幣需求或外國發行人確有特	該公司本次係辦理國內現金增資發行新股，故不適用。

自律規則條款	說明
殊需求，且發行條件合理者，不受此限。	
第四條之七：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認購)辦法中應訂明發行公司或外國發行人依發行與轉換(認購)辦法所定反稀釋調整公式計算其調整後轉換價格時，其公式中之已發行股數應加計已私募股數。 承銷商輔導發行公司或外國發行人申報(請)發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認購)辦法中應訂明發行公司或外國發行人發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券後，除發行公司或外國發行人所私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，發行公司或外國發行人遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，發行公司或外國發行人應比照該發行與轉換(認購)辦法所定於遇有已發行普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時之轉換價格調整公式，計算其調整後轉換價格(向下調整，向上則不予調整)並函請證交所或櫃檯買賣中心公告，於私募有價證券交付日調整之。 依第二項計算調整後轉換價格時，如須訂定每股時價，應以私募有價證券交付日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之八：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換(交換、認購)性質之各種有價證券，公開說明書中應充分揭露當次發行有價證券之發行條件及該發行	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。

自律規則條款	說明
條件對股權稀釋、股東權益之影響。	
第四條之九：除上市(櫃)公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理案件外，發行公司或外國發行人得先行印製價格以區間方式揭露之公開說明書寄交投資人，並於該公開說明書封面顯著處註明提醒投資人上網查詢、參閱承銷商配售通知之實際承銷價格並依承銷商之通知繳交價款。 承銷商應注意交寄當日發行公司或外國發行人須將該公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站，另價格確定後二日內須將完整公開說電子檔傳送至金管會指定之網站。 第一項公開說明書上揭露之價格區間應與承銷商辦理詢價公告之預計承銷價格之可能範圍一致。	本承銷商與該公司本次辦理現金增資發行普通股申請初次上市案件，將採競價拍賣及公開申購配售方式辦理公開承銷，將依左列規定辦理。
第四條之十：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有股權轉換(認購、交換)性質之各種有價證券，若發行條件中包含債券持有人之賣回權利，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換(認股、交換)辦法中應訂明債券持有人行使賣回權之款項支付日。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之十一：承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權性質之各種公司債，應注意發行公司或外國發行人應依財務會計準則公報第34及36號規定設算應負擔年息總額是否符合公司法第249條第2款及第250條第2款之規定。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之十二：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後三個月內不得買回本公司股份。 現金增資發行新股案件，前項承諾書應承諾自申報日起至該有價證券掛牌後一個月內不得買回本公司股份。	該公司本次申報現金增資發行新股已出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後一個月內不得買回該公司股份，故符合左列規定。

自律規則條款	說明
第四條之十三：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募集人民幣計價海外公司債時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書及到期償債資金來源之計畫，承諾海外募得人民幣資金係供海外營運實體使用，不以任何方式匯回臺灣。	該公司本次係申報現金增資發行新股，故不適用。
第四條之十四：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於公開說明書記載發行公司、發行公司之董事、監察人、總經理、財務長以及與發行公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人，絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等之聲明書，並依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」編製公開說明書及簡式公開說明書，且於申報募資案件及向本公會申報承銷契約前，檢核上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容具完整性。	該公司已依左列規定取得聲明書，彙編於公開說明書並上傳。
第四條之十五：承銷商輔導外國人發行人辦理申報「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第一項第一款至第三款募資案件時，應於募集完成年度及其後二個會計年度，協助其遵循中華民國證券相關法令。	該公司此次係本國發行公司辦理國內現金增資發行新股，故不適用。
第四條之十六：承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應就發行公司或外國發行人之財務業務狀況製作檢查表，並於發行公司或外國發行人向金管會申報案件前五個營業日，向證交所或櫃買中心申報。	該公司本次現金增資發行普通股係供初次上市公開承銷用，故不適用左列條款之規定。
第五條：承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股，應於申報案件時出具發行公司或外國發行人之子公司不得參與新股認購之承諾	該公司並非已上市(櫃)公司，故不適用左列之規定。

自律規則條款	說明
書。	
第五條之一：承銷商輔導上市(櫃)公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如申請延長募集期間且其財務預測無重大變動者，應檢送由發行公司或外國發行人出具經會計師複核之財務預測仍屬有效性聲明書。	該公司並未公告財務預測，故不適用左列規定。
第五條之二：承銷商輔導發行公司或外國發行人以現金增資發行普通股申請初次上市（櫃）案件，除另有規定外，向金管會或其委託之機構申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委託之機構申報案件前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成；如經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，得採股數區間方式辦理申報，並敘明實際發行價格或股數如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。 以現金增資發行新股辦理股票初次上市、上櫃前之承銷案件，主辦承銷商應與發行公司或外國發行人約定，由發行公司或外國發行人協調股東按該次現金增資對外公開銷售之一定比例之已發行普通股股票，供主辦承銷商於承銷期間進行過額配售，並應依本公會「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」辦理。	本承銷商本次輔導該公司辦理現金增資發行普通股，謹遵守左列規定。相關評估內容請參閱評估報告陸之說明。
第六條：承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算	截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市(櫃)公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上市公開承銷之用，故不適用左列之規定。

自律規則條款	說明
術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。 承銷商輔導興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格除不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值外，應參考向本公會報備承銷契約前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之均價，並應提出合理說明。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	
第六條之一：承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股，如發行公司依證券交易法第二十八條之一第三項規定，決議提撥發行新股總額超過百分之十對外採公開申購配售辦理承銷，其發行價格訂定方式應提報公司股東會。	截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市(櫃)公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上市公開承銷之用，故不適用左列之規定。
第七條：承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，如採詢價圈購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成；如採競價拍賣方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理競價拍賣公告時，皆	截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市(櫃)公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上市公開承銷之用，故不適用左列之規定。

自律規則條款	說明
不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	
第七條之一：承銷商輔導上櫃(市)公司申請轉上市(櫃)為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件經股東會決議原股東全數放棄優先認股，採公開申購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理公開申購公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。承銷商輔導發行公司向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上市公開承銷之用，非為上櫃(市)公司申請轉上市(櫃)為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件，故不適用左列之規定。
第八條：採詢價圈購配售辦理之承銷案件，於承銷契約報本公會前，如發行價格偏離市場價格過大者，應重新辦理詢價，並於詢價後，隨即進行承銷作業。	本承銷商與該公司本次辦理現金增資發行普通股申請初次上市案件，將採競價拍賣及公開申購配售方式辦理公開承銷，故不適用左列之規定。

自律規則條款	說明
承銷商於向本公會申報承銷契約時，應一併檢送下列資料： 一、詢價圈購之相關資料(含詢價期間、詢價範圍、各圈購價格及其圈購股數、詢價公告暫訂發行價格占詢價公告日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之成數等資料)。 二、配售原則及預計配售予自然人、法人及本公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十六條第一項第一款至第七款有關董事、監察人、大股東、關係人等之股數及配售比率。 承銷商於向本公會申報承銷契約後，應隨即辦理承銷公告及相關承銷事宜。	
第九條：承銷商輔導上市(櫃)公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，其發行價格之訂定方式及依公司法第二百六十七條第一項保留員、工承購股份於員、工未認購時之處理方式，均應列成議案經股東會討論並決議通過。承銷商輔導上市(櫃)公司向金管會申報案件，暫訂發行價格不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。實際發行價格不得低於訂價日收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九成。	截至本評估報告出具日止，該公司尚屬興櫃公司，非為上市(櫃)公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供初次申請上市公開承銷之用，故不適用左列之規定。

綜上所述，該公司本次申報辦理現金增資發行新股案件符合中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定，本承銷商本次輔導該公司辦理現金增資發行新股亦將依自律規則之規定辦理。

四、法令之遵循及對公司營運影響

(一)發行人是否符合公司法第一百二十九條、第一百三十條、第一百五十六條第五項、第一百六十七條第三項及第四項、第二百四十六條、第二百四十七條及證券交易法第二十八條之四規定，且無公司法第二百四十九條及第二百五十條、第二百六十九條及第

二百七十條規定之情事

法令	是否符合規定	評估依據
公司法第 129 條： 發起人應以全體之同意訂立章程，載明下列各款事項，並簽名或蓋章： 一、公司名稱。 二、所營事業。 三、採行票面金額股者，股份總數及每股金額；採行無票面金額股者，股份總數。 四、本公司所在地。 五、董事及監察人之人數及任期。 六、訂立章程之年、月、日。	是	經檢視該公司之公司章程，業已於章程明訂左列各款事項。
公司法第 130 條： 左列各款事項，非經載明於章程者，不生效力： 一、分公司之設立。 二、分次發行股份者，定於公司設立時之發行數額。 三、解散之事由。 四、特別股之種類及其權利義務。 五、發起人所得受之特別利益及受益者之姓名。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
公司法第 156 條第 5 項： 股東之出資，除現金外，得以對公司所有之貨幣債權、公司事業所需之財產或技術抵充之；其抵充之數額需經董事會決議。	不適用	該公司本次係辦理現金增資發行新股，係以現金出資，故不適用左列之規定。
公司法第 167 條第 3 項及第 4 項： 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，不得將控制公司之股份收買或收為質物。 前項控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數者，他公司亦不得將控制公司及其從屬公司之股份收買或收為質物。	是	經查閱該公司最近期經會計師查核簽證之財務報告及股東名冊，並未發現該公司及上述被投資公司有違反左列規定之情事。
公司法第 246 條： 公司經董事會決議後，得募集公司債，但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。 前項決議，應由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意行之。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
公司法第 247 條：	不適用	該公司本次募集與發行有價證

法令	是否符合規定	評估依據
公司債之總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額。 無擔保公司債之總額，不得逾前項餘額二分之一。		券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
證券交易法第 28 條之 4： 已依本法發行股票之公司，募集與發行公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，依下列規定辦理，不受公司法第二百四十七條規定之限制： 一、有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百。 二、前款以外之無擔保公司債，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之二分之一。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
公司法第 249 條： 公司有下列情形之一者，不得發行無擔保公司債： 一、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實已了結，自了結之日起三年內。 二、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債，應負擔年息總額之百分之一百五十。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
公司法第 250 條： 公司有左列情形之一者，不得發行公司債： 一、對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者。 二、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債應負擔年息總額之百分之一百者。但經銀行保證發行之公司債不受限制。	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。
公司法第 269 條： 公司有左列情形之一者，不得公開發行具有優先權利之特別股 一、最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，不足支付已發行及擬發行之特	不適用	該公司本次募集與發行有價證券係以現金增資發行普通股之方式，故不適用左列之規定。

法令	是否符合規定	評估依據
別股股息者。 二、對於已發行之特別股約定股息，未能按期支付者。		
公司法第 270 條： 公司有下列情形之一者，不得公開發行新股 一、連續二年有虧損者；但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限。 二、資產不足抵償債務者。	是	該公司108年及109年度稅後純益分別為(2,643,184)仟元及3,806,477仟元，並無最近連續二年有虧損之情事，且經檢視該公司109年度經會計師查核簽證之財務報告，資產總額為78,914,033仟元，大於負債總額45,696,344仟元，尚無資產不足抵償債務之情形，故無違反左列之規定。

綜上，該公司對上述各項應遵循之法令並未有違反情事，故對該公司之營運及本次有價證券之募集與發行應無不利影響。

(二)發行人是否有證券交易法第一百五十六條第一項各款情事

經取具該公司出具之聲明書，參閱該公司存續有效契約、最近三年度及申請年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會、股東會會議記錄及主管機關往來函文，並參酌傑宇法律事務所陳維均律師所出具之法律意見書及法律事項檢查表，該公司並無證券交易法第 156 條第 1 項各款之情事。請參閱本評估報告「伍、二、(二)、2」之說明。

(三)發行人及其現任董事、監察人、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人與從屬公司最近三個會計年度至刊印日止繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經查閱該公司最近三年度及申報年度之年報、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、董事會、股東會會議事錄，並參酌傑宇法律事務所陳維鈞律師所出具之法律意見書，截至評估報告出具日止，除該公司董事黃崇仁、邵章榮有下列案件外，該公司、該公司之其他董事，目前並無其他尚在訴訟繫屬中之訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，且其結果可能對力積電公司之股東權益或證券價格產生重大影響：

1.董事長黃崇仁 108 年度綜合所得稅經國稅局核定有一筆利息收入，核定應補繳稅額新臺幣 36,099 元，係董事長黃崇仁於 104 年借款予他人，惟借款人至今並未償還本金及利息故並無利息收入，董事長黃崇仁並已向國稅局申請更正。上述情事，目前尚於國稅局審理中，最終若認定須繳稅，僅需繳款並不會有違反稅捐稽徵法之情事。

2.董事邵章榮 108 年度綜合所得稅經國稅局核定有一筆租賃收入，核定應補繳稅額新臺幣 32,499 元，邵章榮董事並無國稅局所核定之租稅收入並已向國稅局申請更正。上述情事，目前尚於國稅局審理中，最終若認定須繳稅，僅需繳款並不會有違反稅捐稽徵法之情事。

3.董事長黃崇仁先生，於民國 94、95 年間擔任力晶半導體股份有限公司（力晶科技股份公司前名稱，下稱力晶公司）董事長時，因董事長職業關係獲悉力晶公司與旺宏電子股份有限公司(下稱旺宏公司)間「買賣晶圓三廠廠房」與「策略聯盟」之重大消息，卻於該消息於 95 年 1 月 18 日公開前即利用力晶集團證券帳戶購買旺宏公司股票，本案黃崇仁最終為無罪確定，故並無有期徒刑以上之罪。其遭投保中心請求侵權行為的損害賠償案，高等法院判決應支付賠償款新臺幣 463 仟元。

經參酌傑宇法律事務所陳維鈞律師所出具之法律意見書，上開案件屬於董事黃崇仁、邵章榮本身之訴訟案件，與力積電公司無涉，故上開案件之訴訟結果不論如何，均不致對該公司之財務、業務產生重大影響。

(四)發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近三個會計年度至刊印日止是否經法院判決有期徒刑以上之罪者

經參閱傑宇法律事務所陳維鈞律師所出具之法律意見書、該公司最近三個會計年度及申請年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告、與主管機關往來文件，該公司發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近三個會計年度至本評估報告刊印日止，並無經法院判決有期徒刑以上之罪情事。

(五)發行人及其各子公司目前仍有效存續、最近一個會計年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

該公司最近年度及本年度截至申請時仍有效存續及締結之重要契約條款如下表：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術合作契約	日商 Micron Japan 公司	92.08~110.07	技術移轉與授權	無
聯貸合約	臺灣土地銀行(主辦銀行)及其他聯貸銀行等 7 家金融機構	107.01~114.01	中長期借款	財務比率需符合合約所訂標準
聯貸合約	臺灣土地銀行(主辦銀行)及其他聯貸銀行等 6 家金融機構	108.02~113.02	中長期借款	財務比率需符合合約所訂標準
聯貸合約	彰化商業銀行股份有限公司(主辦銀行)及其他聯貸銀行等 14 家金融機構	109.11~116.01	中長期借款	財務比率需符合合約所訂標準
園區土地租金-P1/2 廠	科技部新竹科學園區管理局	108.05.24~127.12.31	承租土地	無
園區土地租金	科技部新竹科學園區管理局	108.05.24~127.12.31	承租土地	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
-P3 廠				
8A 廠科管局土地	科技部新竹科學園區管理局	104.04.01~123.12.31	承租土地	無
8B 廠科管局土地	科技部新竹科學園區管理局	106.09.15~125.12.31	承租土地	無
園區土地租金-P5 廠	科技部新竹科學園區管理局	109.07.01~128.12.31	承租土地	無
嘉晶 8AD 廠	嘉晶電子股份有限公司	103.12.01~115.11.30	承租土地	無
銅鑼園區土地	科技部新竹科學園區管理局	109.07~128.12	承租土地	無

該公司重要契約皆為其基於公司正常營運所需而簽訂，經查閱契約內容，無影響投資人權益之情事。

(六)發行人及其各子公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經參酌傑宇法律事務所陳維鈞律師出具之法律意見書，查閱該公司與主管機關之往來函文，發函勞動部、勞動部職業安全衛生署、科技部新竹科學園區管理局、勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署、新竹市政府環境保護局與苗栗縣政府環境保護局等相關業務主管機關，另並取得該公司出具之聲明書，該公司截至評估報告出具日止，尚無有重大勞資糾紛或污染環境事件。

(七)發行人之資金用途須經目的事業主管機關同意者，其核准之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券之情事

該公司本次籌資計畫之資金用途並無需經目的事業主管機關同意，故對本次募集與發行應無重大影響之情事。

(八)承銷商因前項之評估需要，若有洽請律師出具意見者，應說明事項

本次並無洽請律師對前項評估出具意見，故不適用。

五、說明發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師未具有下列情事

(一)於最近一年內曾受法務部律師懲戒委員會懲戒。

(二)與發行人、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有下列關係之一：

1.依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。

2.其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。

經取具傑宇法律事務所陳維鈞律師所出具之聲明書，其於最近一年內未曾受法務部律師懲戒委員會懲戒，且未與該公司、最近期財務報告簽證會計師及本承銷商間具有主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係，或其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者之關係。

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益是否具有合理性

(一)本次計畫之資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益

1.本次計畫所需資金總額：新台幣 27,147,163 仟元。

2.本次計畫資金來源

(1)現金增資發行普通股 130,000 仟股，每股面額新金幣 10 元，每股發行價格暫定為新台幣 50 元溢價發行，預計募集總金額為新台幣 6,500,000 仟元。

(2)自有資金或銀行借款：20,647,163 仟元。

(3)如本次現金增資發行普通股每股實際發行價格因市場變動而與暫訂發行價格有異，致募集資金不足時，本公司將以自有資金及增加銀行借款金額因應；惟若致募集資金增加時，則將減少銀行借款金額。

3.計畫項目及預定資金運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成時間	所需資金總額	預定資金運用時間								
			截至 110 年前三季(實際數)	110 年第四季(預計數)	111 年第一季(預計數)	111 年第二季(預計數)	111 年第三季(預計數)	111 年第四季(預計數)	112 年第一季(預計數)	112 年第二季(預計數)	112 年第三季(預計數)
P5 銅鑼廠建物廠房(土建/廠務)	112 年第三季	27,147,163	641,302	3,359,096	4,704,247	4,489,517	7,070,866	4,508,156	1,419,039	507,806	447,134

4.預計可能產生效益

因應市場需求增加，晶片的需求大於供給，促使晶圓代工需求大爆發，整體產業狀態明顯供不應求，該公司募集資金，將全數用於擴建廠房(土建/廠務)，以解決目前廠房空間不足的問題外，同時考量未來產能及擴產所需，並配合自動化生產線之設置，規劃與辦公區域空間相整合，以提高公司整體競爭力；預計於竹科銅鑼園區興建力積電 P5 廠 10 年內分階段投資，將視市場需求及公司財務能力逐年擴充產能，預估總投資金額達新臺幣 2,780 億元，將於竹科銅鑼園區，興建兩座晶圓廠，共計 53,000 平方公尺的無塵室面積，10 萬片/月的產能規劃，以本公司與銀行團簽訂之聯貸合約，聯貸案的借款利率約 1.7895%，本次募集資金新台幣 6,500,000 仟元一年預計可為公司節省利息支出 116,318 仟元，且自行興建可達到最佳的空間規劃與節省改建支出。

(二)本次計畫之可行性評估

1.於法定程序上之可行性

該公司本次辦理上市前現金增資發行普通股計畫，業經 110 年 3 月 9 日董事會及 110 年 7 月 2 日股東常會決議通過辦理初次上市前現金增資提撥公開承銷案，並於 110 年 10 月 19 日董事會決議通過本次現金增資股票發行計畫，且授權董事長全權處理相關增資事宜。經查與「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及其他相關法令規定並無不符，並經律師對本次募集現金增資計畫之內容出具法律意見書，顯示本次現金增資發行普通股計畫確已符合相關法令之規定，故該公司本次計畫於法定程序上應屬適法可行。

2.資金募集完成之可行性

該公司本次現金增資發行新股 130,000 仟股，其中依公司法第二百六十七條規定保留百分之十五，計 19,500 仟股由員工認購，餘 110,500 仟股則依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十一條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七條之一規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，並按證券交易法第二十八條之一規定，於 110 年 7 月 2 日股東常會決議通過，排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先認購之適用。

該公司本次辦理現金增資發行新股係採部份競價拍賣，部份公開申購方式辦理，員工認購不足或放棄認購部分，將授權董事長按發行價格洽特定人認購之，而對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，應可確保資金募集完成，故該公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

3.資金運用計畫之可行性

本次預計募集資金新台幣 6,500,000 仟元，預計於 110 年第四季完成募集，資金運用進度係考量申報及募集資金所需之作業時程而定，於資金到位後，即可於 110 年第四季投入支應擴建廠房之土建/廠務資金需求，減輕公司財務負擔並進而滿足中長期營運規劃，該公司已於 109 年 7 月正式向竹科銅鑼園區租地，規劃以 10 年期建構 12 吋生產基地並命名為力積電 P5 廠，110 年 3 月 25 日 P5 廠動土典禮完成後，建廠正式展開。第一期規劃包含第一座晶圓廠、廠務棟及整個廠區(含第二座)的地下基礎建築，初步以月產能 3 萬片為目標，依據工程進度規劃，並配合興建作業時程進行預估資金運用計劃，故本次籌資計畫之資金運用應具可行性。

(三)本次計畫之必要性評估

該公司本次辦理現金增資發行新股係依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第 11 條規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上市前公開承銷，故本次辦理現金增資發行新股係配合主管機關初次上市新股承銷制度予以辦理，實有其必要性。

(四)本次計畫之合理性評估

1.資金運用計畫及預計進度之合理性

該公司本次增資計畫之資金運用進度係考量向臺灣證券交易所股份有限公司申報及募集資金所需之作業時程而訂，預計於 110 年第四季完成資金募集作業。於本次資金挹注下將配合本公司銅鑼 P5 廠計畫，銅鑼廠(P5 廠)長期規劃是以十年期建構雙子星式的 12 吋晶圓廠(共兩座)，月產能共計 10 萬片。第一期規劃包含第一座晶圓廠、廠務棟及整個廠區(含第二座)的地下基礎建築，初步以月產能 3 萬片為目標，預估土建/廠務資金需求為新臺幣 27,147,163 仟元，目前已與科技部新竹科學園區管理局簽訂土地租賃契約，取得確切期間之土地使用權，於 110 年 3 月動土，係依據工程規劃進度，並配合與建作業時程進行預估資金運用計劃，評估其資金運用及預計進度尚屬合理。

2.預計可能產生效益之合理性

該公司擴建廠房，主係因應未來營運產能日益不足之問題，預計於竹科銅鑼園區興建力積電 P5 廠 10 年內分階段投資，將視市場需求及公司財務能力逐年擴充產能，預估總投資金額達新臺幣 2,780 億元，將於竹科銅鑼園區，興建兩座晶圓廠，共計 53,000 平方公尺的無塵室面積，10 萬片/月的產能規劃，以本公司與銀行團簽訂之聯貸合約，聯貸案的借款利率約 1.7895%，本次募集資金新台幣 6,500,000 仟元一年預計可為公司節省利息支出 116,318 仟元，另依照本公司承租 8AD 廠及購買 8B 廠改建經驗，由於舊有建築物並非專門供晶圓廠使用，機台擺設位置、各工作站動線安排、樓地板荷重程度、倉儲與出貨動線等皆須要經過規劃與修改，依照建築物屬性不同，投入改建的資金也會有所不同。如果自行興建應可達到最佳的空間規劃與節省改建支出，故其預計可能產生效益應具合理性。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資，其資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益應具合理性。

二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估

該公司本次募資計畫係依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式辦理初次上市前之公開銷售作業，故僅就發行新股對本年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

該公司本次辦理現金增資發行普通股 130,000 仟股，占該公司擬掛牌股本 3,535,196 仟股之 3.68%，本次增資預計於 110 年第四季募集完成，考量該公司未來整體營運應能維持穩定成長之趨勢，故本次現金增資發行新股對 110 年度每股盈餘稀釋之影響尚屬有限。

三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、

支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性

(一)本次募集與發行有價證券資金計畫用於轉投資者之評估

該公司本次募集資金並非用於轉投資，故不適用本項評估。

(二)本次募集與發行有價證券資金計畫用於償債或充實營運資金者之評估

該公司本次募集資金並非用於償債或充實營運資金，故不適用本項評估。

(三)本次募集與發行有價證券資金計畫如用於購置營建用地或支付營建工程款者，就預計自購置土地至營建個案銷售完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點與金額，評估可能產生效益是否具有合理性

該公司本次募集資金並非用於購買營建用地或支付營建工程款，故不適用本項評估。

(四)本次增資計畫如用於購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應就其賣方轉讓之理由、受讓價格之依據評估其合理性，並評估其受讓過程是否適法及對契約相對人權利義務之影響

該公司本次募集資金並非用於購買未完竣工程或承受賣方未履行契約者，故不適用本項評估。

三之一、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性

該公司本次辦理現金增資發行新股係採現金出資方式，故不適用此評估項目。

四、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應評估其可行性與合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股未併同減資計畫辦理，故不適用此評估項目。

五、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響

該公司本次辦理現金增資發行新股係以溢價發行，故不適用此評估項目。

六、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式者，應評估事項：

(一)已上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股原股東未放棄優先認股，採公開申購配售方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性

該公司為申請股票初次上市公司，且已於 110 年 7 月 2 日股東常會決議通過原股東全數放棄優先認購權，故不適用此評估項目。

(二)已上市(櫃)公司辦理現金增資，經股東會已決議原股東全數放棄優先認購，採全數

詢價圈購或競價拍賣方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性。及暫定發行股數區間是否符合公司法第一百二十九條第三款規定之情事

該公司為申請股票初次上市公司，故不適用此評估項目。

(三)以現金增資發行普通股申請初次上市(櫃)案件向金管會申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，並敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，其適法性及合理性

該公司於 110 年 10 月 19 日經董事會決議辦理現金增資發行普通股 130,000 仟股，每股面額 10 元，暫定以每股 50 元溢價發行，暫定之發行價格係依一般市場承銷價格訂定方式，參考市場法以及該公司近一個月之興櫃市場平均成交價等方式，以推算合理之承銷價格。

本次現金增資之重要內容，包括但不限於發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，已於 110 年 10 月 19 日董事會授權董事長全權處理，故本次現金增資於法定程序應屬可行。若每股實際發行價格因市場調整變動，致募集資金不足時，其差額將以自有資金支應，惟若募集資金增加時，則調整增加充實營運資金金額，故其募集資金增加或不足之資金用途及預計效益，皆具適法性及合理性。

(四)公司債未足額發行者，需就募集資金不足時之處理方式之合理性予以說明

該公司本次係為現金增資發行新股，故不適用本項評估。

七、發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

捌、就本次公司債發行（及轉換）辦法之下列各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權公司債持有

者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

拾、就本次發行公司債債權確保情形（列明有無擔保、擔保品種類與價值等）蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果

該公司本次辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

無。

主辦承銷商：元大證券股份有限公司

負責人：陳修偉

中　華　民　國　一　一　〇　年　10　月　19　日

(僅供力晶積成電子製造股份有限公司辦理一一〇年度現金增資發行新股證券承銷商評估報告使用)

力晶積成電子製造股份有限公司

董事長：黃崇仁